'88 THE TRANSISTOR MANUAL

最新トランジスタ規格表

復刻版

最新トランジスタ規格表

このページは空白です.

規格表の使い方

☆規格表ご利用の際のお願い

本規格表の仕様はメーカー発表の資料に基づき作成しておりますが，メーカーによって予告なく規格・外形等を変更する場合がありますので，量産品等，大量に素子を使用して製品を生産する必要のある際には，事前に該当メーカーにお問合わせの上，仕様をご確認ください。

このページは空白です.

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)												外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE} V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real) (Ω)		
1	2	3	4	5					6		7		8						9	10	11	12

1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO ·····

トランジスタ規格表 使い方の手引

トランジスタは上手に使えば非常に長い寿命を持つものですが，定格をオーバーしたり，少し無理な使い方をすると，真空管とは比べものにならないほど弱いものです．そこでトランジスタを使う前に，できれば買う前にそのトランジスタの特性や規格を良く調べて，最も適した使い方をすることが大切です．

ここでお目にかける規格一覧表は電子機械工業会（EIAJ）に登録されているすべてのトランジスタを集めています．この中にはNTTやNHKの専用品種，あるいはメーカーが通信・工業用として作った，特殊な用途の品種も含まれています．トランジスタを扱う人達が多方面の技術あるいは資材，営業の人達に広がって来ていることから，この規格一覧表をできるだけ多くの人達に利用していただくために全品種をとりあげることにしたわけです．

トランジスタ・メーカーで試作的に作ったものは例外ですが，一般に販売するトランジスタはすべてEIAJに登録されたものでなければならないことになっていますので，これで私達が国内で入手し得る国産のトランジスタのほとんど全部ということです．EIAJでは加盟会社以外であっても登録を受けつけているので，EIAJ登録された海外のメーカーの品種も含まれています．

本規格表では資料は原則としてEIAJに登録されたものを用い，これを入手できるかぎりのメーカーの最新のカタログと比較して補ってあります．したがって，EIAJ登録とメーカーのカタログとがくい違ったときは，メーカーのカタログを優先してあります．この規格一覧表で使用した記号，略号は次のとおりです．

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)												外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$ (Ω)		
1	2	3	4	5					6		7			8						9	10	11	12

1 EIAJに登録されたトランジスタ型名です．

2 その型名と規格をEIAJに登録した会社名です．

3 EIAJに登録された時の用途を示しました．したがってこれ以外の用途に使えないというわけではありません．

4 トランジスタの材料と，構造名を書きました．いずれもEIAJに登録された時のものです．

5 トランジスタの最大定格です．

6 I_{CBO}の最大値と，その測定条件であるV_{CB}の値です．

7 直流h_{FE}またはパルスh_{FE}の標準値と，その測定条件であるV_{CE}, I_Cの値です．

8 hパラメータの標準値とその測定条件であるバイアスV_{CB}, I_Eの値です．
通常エミッタ接地の値ですが，＊印をつけた場合はベース接地の値を示します．

9 高周波特性の$f_{\alpha b}$です．＊印をつけた場合はf_Tの値を示します．

10 高周波特性のC_{ob}と$r_{bb'}$です．$r_{bb'}$の欄で＊印をつけた場合は$h_{ie(real)}$の値を示しました．

11 この規格表のあとの方にまとめた外形図の番号です．

12 必要に応じて，そのトランジスタについての特別な注釈を加えました．

《各項目のくわしい説明は次頁以下の各□番号のところを参照してください》

トランジスタを活用するための規格表の見方

1 型　名

トランジスタはJISのトランジスタ型名付与法（JIS-C-7012）にもとづいて決められた型名と，規格をEIAJに登録することになっています．EIAJというのは電子機械工業会で，現在ではこの登録の業務はEIAJの電子デバイス登録センターで行っていますが，一般にはEIAJ型名 正しくはJIS型名といいます．この名前のつけ方は次のようになっています．

2S	文字	数字	文字
（例）2S	A	708	A

最初の2Sは有効電極数が3の半導体素子を表します．

ダイオードでは1S，有効電極数が4のトランジスタ（4極トランジスタのような）では3Sを用います．

2Sにつづく文字はトランジスタとしてはA，B，C，Dのいずれかを使います．その使いわけは次のとおりです．

A……PNP型の高周波用
B……PNP型の低周波用
C……NPN型の高周波用
D……NPN型の低周波用

高周波と低周波の区別はあまり明確ではなく，登録するメーカーの指定用途によっているので，f_Tが200MHzくらいの低周波用があったり，逆に50MHzぐらいの高周波用があることもあります．2Sに続く文字は他の構造の素子にはまた別の文字を使うことになっており，本規格表では関係ありませんが一例を紹介しておくと，次のようなものがあります．

F……単方向サイリスタ(例：SCR)
H……単接合トランジスタ
J……PチャンネルFET
K……NチャンネルFET
M……双方向サイリスタ（例：トライアック）

次にこのA，B，C，Dの文字につづく数字は，登録順につける番号で11から始めることになっています．

最後の文字は改良品種を示すもので，最初はつけません．改良品種ができるごとにA，B，C，D，E，F，G，H，J，Kまでつけられます．

改良品種は前の品種に置きかえて使えることが必要ですが，逆のおきかえ，つまり改良品種の代わりに前の品種が使えないことはあり得るわけです．

以上の原則にしたがってトランジスタ型名をながめて見ると，たとえば2SA708AというのはPNP高周波用トランジスタで，708番目の品種（11番から始めるので，正確には698番目に登録された品種）である2SA708の改良品種というわけです．

この改良を示す文字については，上記のA～Kのほかに，各社で独自にきめた文字たとえばⓈ，Ⓗ，(1)などを使うことがあり，この場合には必ずしも改良とは限らない場合があるので，各社のカタログを調べてみる必要があります．メーカーによってはEIAJに登録して，EIAJ型名がきまっていながらそれを使わないで，各社型名でカタログを作ったり，現品表示をしたりしている場合もあります．

2 社　名

原則としてそのトランジスタの型名と規格をEIAJに登録した会社名を書きました．これをオリジナルの登録会社といいます．

まれにはオリジナルが2社以上の連名で

登録されている場合もあります．

EIAJに登録が完了すると，その型名と規格は業界共有のものとされ，オリジナルの登録会社以外の会社がその型名のトランジスタを生産してもよいことになっています．本規格表では次のような略称を使いました．

これらのメーカーの中にはすでにトランジスタの製造をやめていたり，あるいは会社そのものが現存しない場合もあるのですが，いったんEIAJに登録した型名と規格はなくなるわけではないので，オリジナルの登録会社名を書くことにしてあります．

オリジン	オリジン電気株式会社
富士通	富士通株式会社
富士電機	富士電機株式会社
日立	株式会社日立製作所
松下	松下電子工業株式会社
三菱	三菱電機株式会社
日電	日本電気株式会社
沖	沖電気工業株式会社
サンケン	サンケン電気株式会社
三洋	三洋電機株式会社
新電元	新電元工業株式会社
ソニー	ソニー株式会社
東芝	株式会社 東芝
富士ゼネ	株式会社 富士通ゼネラル(現在は製造していない)
東光	東光株式会社
芝電	芝電気株式会社(現存しない)
新日無	新日本無線株式会社（現在は製造していない）
モトローラ	日本モトローラ株式会社
ローム	ローム株式会社
韓國電子	韓國電子株式会社

3 用　途

原則としてEIAJに登録された用途です．EIAJ登録の用途とメーカーのカタログでの用途がくいちがっているときはメーカーのカタログの方を優先しました．したがって，使い方によっては，これ以外にでも使えることはもちろんです．本規格表では次のような記号を使ってあります．

AF	低周波増幅
Conv	周波数変換
Ch	チョッパ
Diff	差動増幅
IF	中間周波増幅
LN	低雑音増幅
Mix	周波数混合
Osc	発振
PA	電力増幅
RF	高周波増幅
SW	スイッチング

4 構　造

トランジスタの材料がゲルマニウムであるかシリコンであるかをまず書き，次に主として接合の作り方やパッシベーションに着目した構造を示しました．これらはいずれもEIAJで分類した方式によっており，商品名のようなものは使っていません．

トランジスタを使う立場からみると，接合の作り方の構造など，どうでもよいように思えますが，トランジスタの各種の特性やそのバイアス依存性などはこの構造によって，あるていど推定できる似た傾向をもっているので，それぞれの特長をつかんでおくと便利です．本規格表では次のような記号を使ってあります．

Ge	ゲルマニウム
Si	シリコン
A	合金接合（アロイ）
AD	合金拡散（アロイ・ディフュージョン）
D	ドリフト
DB	ベース拡散
DJ	拡散接合
E	エピタキシャル
E_b	エピタキシャル・ベース
EMe	エピタキシャル・メサ
EP	エピタキシャル・プレーナ

G	成長接合（グロン）
GD	成長拡散（グロン・ディフューズド）
MA	マイクロ合金接合（マイクロ・アロイ）
MD	マイクロ・ドリフト
Me	メサ
P	プレーナ
T	三重拡散
TMe	三重拡散メサ
TP	三重拡散プレーナ
Pa	パッシベーテッド

5 最大定格

これ以上の条件で使うとトランジスタがこわれる危険があるという限界で，メーカーの示す警告とみていただきたいと思います．ただしトランジスタによって丈夫なものもあり，弱いものもあるので，この限界を越えても，直ちに全部こわれるわけではありません．また程度によってはすぐにはこわれず，寿命が短くなるということも考えられます．本規格表では次のような記号を使ってあります．

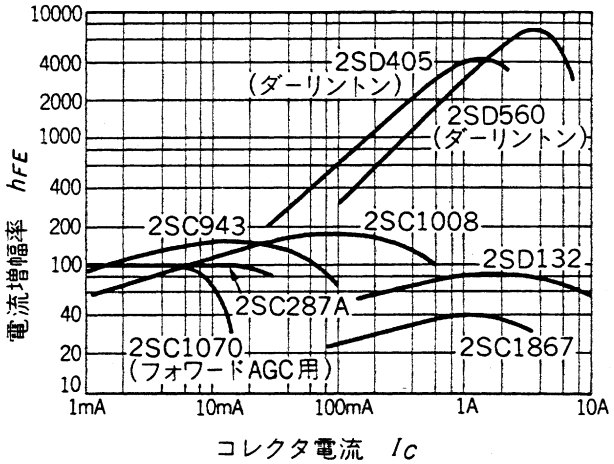
V_{CBO}	コレクタ-ベース間電圧
V_{CEO}	コレクタ-エミッタ間電圧
I_C	コレクタ電流
P_C	コレクタ損失（周囲温度 T_a，ケース温度 T_c の二通りの規定方法があり，通常 T_a＝25°C）
T_j	接合部温度（ジャンクション温度ともいう）

一般に V_{CBO}，V_{CEO} 等の耐圧は，PN 接合のブレークダウン電圧の制限から決められるので，これら電圧の最大定格は厳密に守らないと危険です．CE 間耐圧は原則としてベース開放の条件である V_{CEO} で記載しましたが，V_{CER} の場合には数値の次にRをつけました．また V_{CES} の場合には同じく数値のあとにSを，V_{CEX} の場合には数値のあとにXをつけて記載しました．

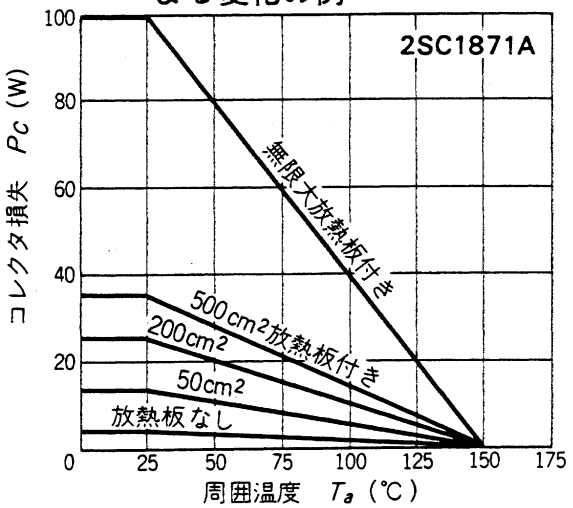
電流の最大定格である I_C は，普通はこわれる限界というよりは**図1**のように大電流のところで h_{FE} が低下して歪が増し，増幅素子として満足に動作しなくなる限界で決めていますから，少しぐらいこれを越えてもこわれないことが多いようです．ただ大きな電流のところではコレクタでの電圧降下 $V_{CE(sat)}$ が急激に増加して，コレクタ消費電力が増すことに注意しなければなりません．また非常に大きな電流のところでは二次ブレークダウンの現象を起こして急激に耐圧が数Vに低下してしまうこともあるので，あまり極端な定格オーバは避けなければなりません．

コレクタ損失はコレクタで許容できる電力損失です．コレクタで電力を消費すると熱となり，内部の温度を上昇させますから，

〈図1〉 h_{FE} の電流による変化の一例



〈図2〉 T_a-P_C カーブと放熱条件による変化の例



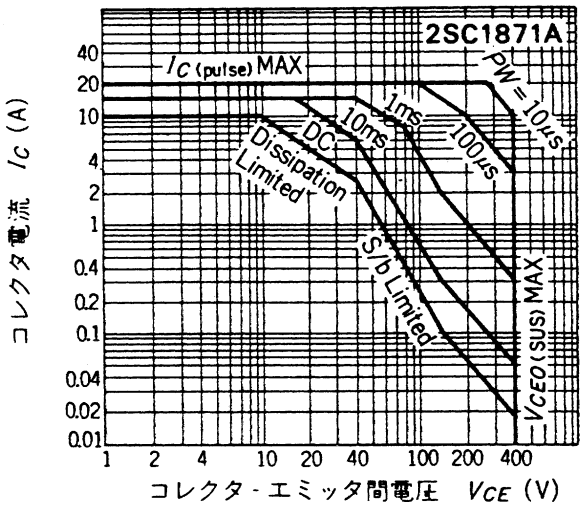
接合部（内部のトランジスタ動作をしている部分）での温度の限界 T_j との間に**図2**のような関係があります．つまり25°C以上の温度では，25°Cの P_C と T_j とからこの図を書いて，許容し得る P_C を割り引きして考えなければなりません．そして T_j（接合部温度の最大定格）のところでは，許容できる P_C はちょうどゼロとなります．

P_C の規定には周囲温度（T_a）25°Cの時の値とケース温度（T_c）25°Cの時の値と二通りの規定方法があり，一般にパワー・トランジスタではケース温度を基準にしています．

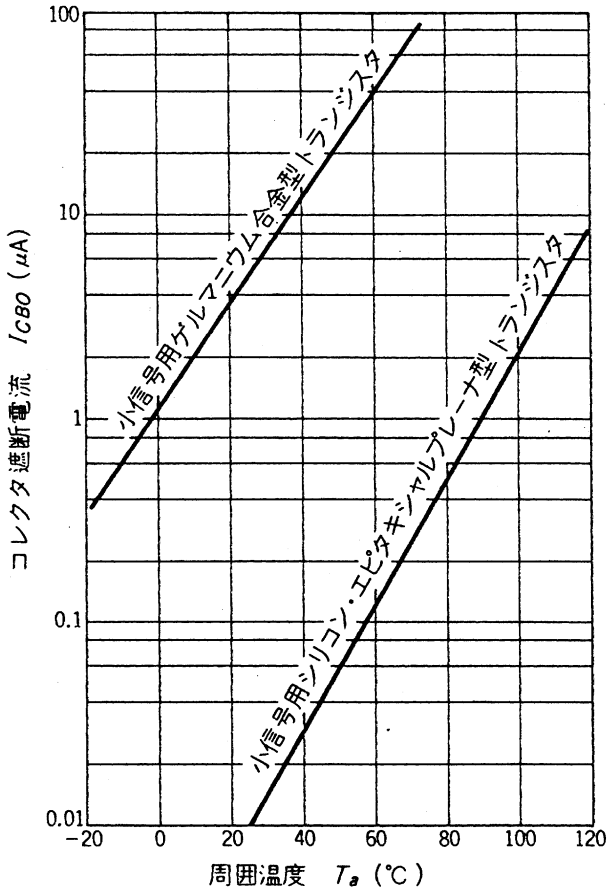
ケース温度25°Cというのは，周囲温度が25°Cの時に無限に大きい放熱板をつけるかまたは猛烈な風を送って強制空冷にしたときの理想的な値であり，実用上考えられるような適当な大きさの放熱板では，許容し得る P_C はこれよりも小さい値になってしまうことに注意しなければなりません．**図2**はこの例です．

本規格表では通常 T_a＝25°C すなわちフリーエアの P_C の場合は数値だけを書き，T_c＝25°C すなわち無限大放熱板の P_C の場合は P_C の数値の下に（T_c＝25°C）と書き添えました．これらの P_C はいずれも直流での $V_{CE}\times I_C=P_C$ という考え方ですが，非常にパルス幅の短い，瞬時としてはもっと大きい P_C で使いたいこともあります．このような瞬時定格としては**図3**のようなデータがメーカーのカタログにのっている場合があるので，それを参考にしてください．

〈図3〉 P_C の瞬時定格の例



〈図4〉 I_{CBO} の温度特性例



6 コレクタ遮断電流 I_{CBO}

コレクタ-ベース間に逆方向電圧をかけた時の漏れ電流で，小さいものほど良いとされていますが（**図4**），シリコン・トランジスタではある程度小さい値になると実用上は全く影響しなくなります．温度によってはほぼ10°C上昇するごとに2倍になり，非常に大きく変わるので，25°Cの時の値を示すことにしています．ふつうは規格の最大値を書きますが，実際の中心値はシリコン・トランジスタでは小型のもので0.0001～0.001μA，パワー・トランジスタで10μA～1mA程度となっています．

本規格表では，この欄は左側に I_{CBO} の最大値を書き，右側の欄には，その I_{CBO} を測定した条件であるコレクタ電圧 V_{CB} を書きました．

7 直流電流増幅率またはパルス電流増幅率 h_{FE}

直流で測ったエミッタ接地電流増幅率，つまりコレクタ電流 I_C をベース電流 I_B で割った I_C/I_B をいいます．

スイッチング用あるいはパワー用トランジスタ等では，大電流で使うため小信号パラメータでは設計できないからです．さらに大きな電圧，電流で測るものになると，そのバイアスによる電力で発熱してしまうので，非常に短い時間だけ電流を流してパルス的に測ることも行われます．これをパルス h_{FE} といいます．これらはいずれもバイアス，特に電流によって大きく変わるので h_{FE} の大小を論ずる時には必ず測定条件も考えなければいけません．

図 1 のように小電流で使うものは少ない電流で早く立上り，大電流のところで低下してしまうのに対し，大電流用のものは立上りは遅いかわりに大電流のところまで h_{FE} が低下しないように設計されています．

本規格表では，この欄は一番左側に h_{FE} の標準値を書き，右側の 2 つにはその h_{FE} を測定した条件であるコレクタ電圧 V_{CE} とコレクタ電流 I_C を書きました．

メーカーのカタログが標準値で規定せず 50～240のように範囲で規定してあるものについては，その範囲で書いてあります．

8 h パラメータ

h パラメータには電流増幅率 h_f，入力インピーダンス h_i，電圧帰還率 h_r，出力アドミタンス h_o の 4 つがありますが，それぞれにベース接地では b，エミッタ接地では e の添字をつけて区別しています．

h_{fe}	電流増幅率（エミッタ接地）
h_{fb}	電流増幅率（ベース接地）
h_{ie}	入力インピーダンス（エミッタ接地）
h_{ib}	入力インピーダンス（ベース接地）
h_{re}	電圧帰還率（エミッタ接地）
h_{rb}	電圧帰還率（ベース接地）
h_{oe}	出力アドミタンス（エミッタ接地）
h_{ob}	出力アドミタンス（ベース接地）

これらベース接地とエミッタ接地のパラメータは次式で換算することができます．

$$h_{ie}=\frac{h_{ib}}{1+h_{fb}} \qquad h_{ib}=\frac{h_{ie}}{1+h_{fe}}$$

$$h_{fe}=\frac{-h_{fb}}{1+h_{fb}} \qquad h_{fb}=\frac{-h_{fe}}{1+h_{fe}}$$

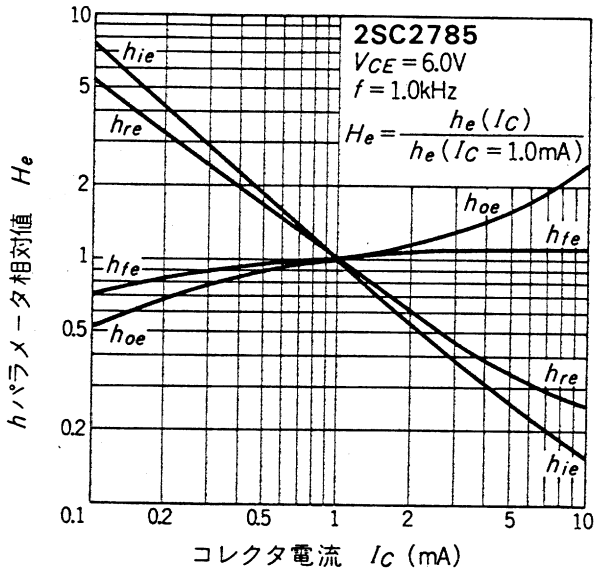
$$h_{re}=\frac{h_{ib}\times h_{ob}}{1+h_{fb}}-h_{rb} \qquad h_{rb}=\frac{h_{ie}\times h_{oe}}{1+h_{fe}}-h_{re}$$

$$h_{oe}=\frac{h_{ob}}{1+h_{fb}} \qquad h_{ob}=\frac{h_{oe}}{1+h_{fe}}$$

これらはいずれもバイアスにより大幅に変化するものです．**図 5**，**図 6** は代表的なシリコン・トランジスタの h パラメータのバイアスによる変化です．

本規格表ではこの欄はまず測定条件であるコレクタ電圧 V_{CB}，エミッタ電流 I_E を書き，次に h_{fe}，h_{ie}，h_{re}，h_{oe} の順に並べました．通常エミッタ接地での標準値ですが，＊印をつけた場合はベース接地の値を示し

〈図 5〉 h パラメータの電流特性例



ます．hパラメータは一般に1 kHzの低周波の値を示しますが，エミッタ接地電流増幅率h_{fe}だけは高周波での値も示すメーカーがあります．この場合，高周波h_{fe}は単位なしの値（倍率）の時と，dBの時とあるので注意が必要です．

なお，この欄はhパラメータが規定されないで空欄となっている時などには，動作例，例えば電力利得がG_{pe}=25dB（f=1MHz）とか，スイッチング時間がt_{on}<80ns t_{stg}<200ns t_{off}<400nsなどのようにhパラメータではないものを記入した場合もあります．

これには次のようなものがあります．

NF　　雑音指数

G_PまたはPG	増幅電力利得	動作例
G_CまたはCG	変換電力利得	動作例
P_O	出力電力	動作例
t_d	遅延時間	スイッチング時間
t_r	上昇時間	スイッチング時間
t_sまたはt_{stg}	蓄積時間	スイッチング時間
t_f	下降時間	スイッチング時間
t_{on}	ターンオン時間	スイッチング時間
t_{off}	ターンオフ時間	スイッチング時間

9　遮断周波数と利得帯域幅積

遮断周波数にはベース接地の$f_{\alpha b}$とエミッタ接地の$f_{\alpha e}$とあって，いずれも電流増幅率が低周波の値より3dB低下する周波数です．ふつうは$f_{\alpha b}$ですが，パワー・トランジスタ等でまれに$f_{\alpha e}$で表示したものがあります．また，シリコン・トランジスタではこれに代わって利得帯域幅積f_Tが良く使われます．f_Tはまたf_1と書かれることもあり，エミッタ接地の電流増幅率が1（＝0dB）となる周波数です．

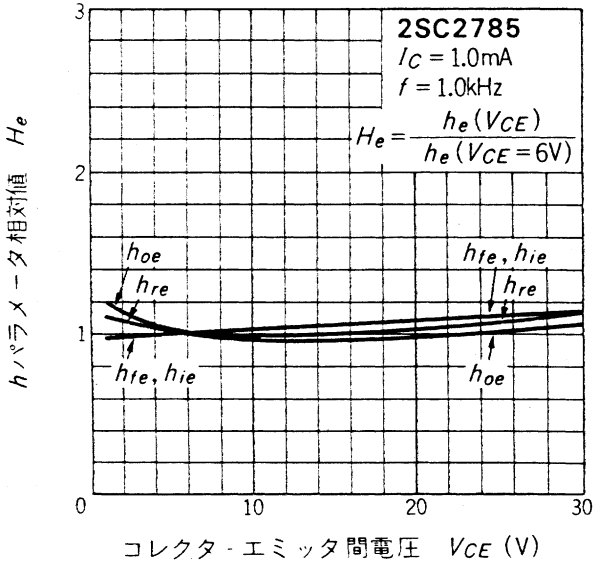
高い周波数でのh_{fe}は**図7**のように周波数に対してオクターブあたり6dBで低下しますから，

f_T＝高周波h_{fe}×測定周波数

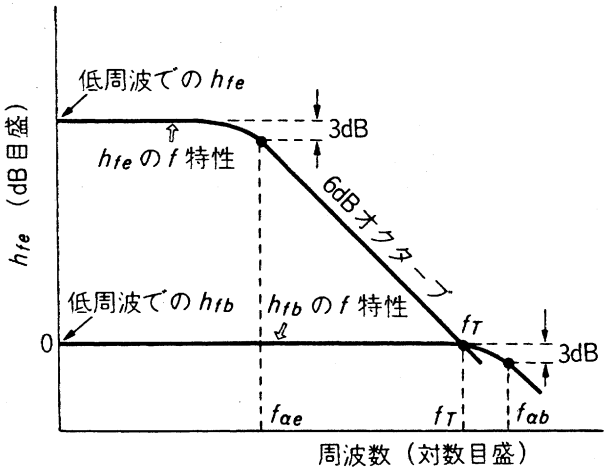
で計算することもできます．f_Tを利得帯域幅積と呼ぶのは，このためです．

これら$f_{\alpha b}$, $f_{\alpha e}$, f_Tはトランジスタの高周波特性を示す一つの目安になるので高い方が良いにはちがいありませんが，必ずしもこの周波数まで使えるという意味ではあり

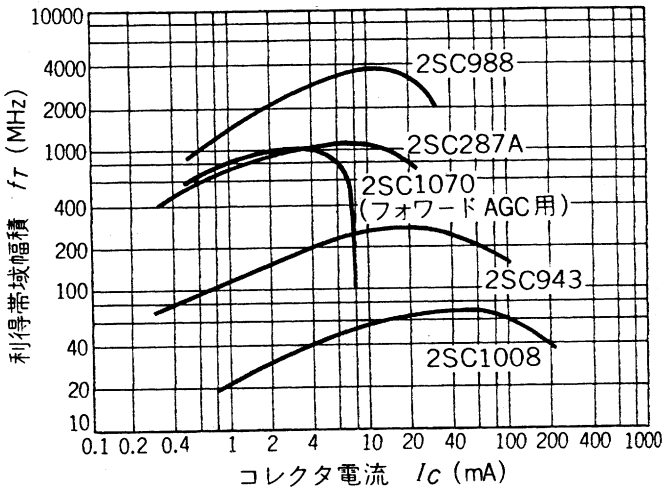
〈図6〉 hパラメータの電圧特性例



〈図7〉 f_T, $f_{\alpha b}$, $f_{\alpha e}$の意味



〈図8〉 f_Tの電流特性例



りません．C_{ob}（正しくは C_c）と $r_{bb'}$ との総合で高周波特性の良し悪しが決まるので，$C_c \cdot r_{bb'}$ が小さければ f_T が低いのを補うことができるからです．

本規格表では f_{ab} の場合にはそのまま値を記入し，f_T の場合には値に＊印をつけました．またごくまれにある f_{ae} の時には $\underset{10\mathrm{kHz}}{f_{ae}}$ のように書いてあります．

f_T もまたバイアスによって大幅に変わるもので，コレクタ電流に対する変化の例を**図8**に示しました．

10 コレクタ容量 C_{ob}，および ベース広がり抵抗 $r_{bb'}$

ベース広がり抵抗 $r_{bb'}$ とコレクタ容量 C_{ob} は，f_T と共にトランジスタの高周波特性を決める大切なパラメータです．電力利得が0dBになる周波数すなわち最高発振可能周波数 f_{max} は

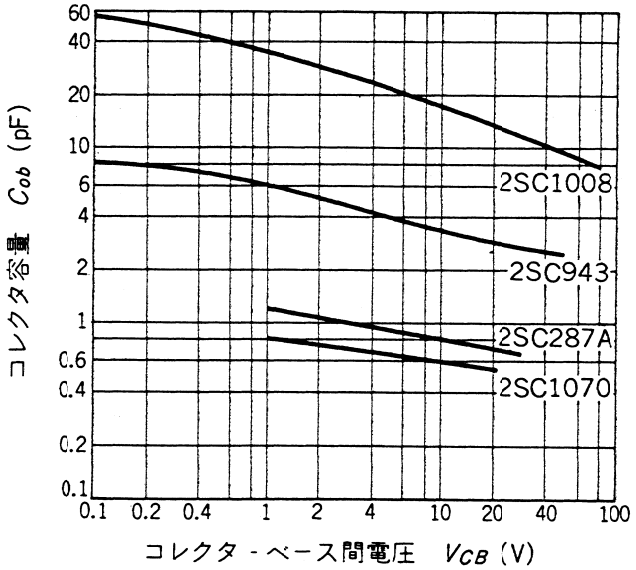
$$f_{max}=\sqrt{\frac{f_T}{8\pi \cdot C_{ob} \cdot r_{bb'}}}$$

で示されますから，C_{ob} と $r_{bb'}$ は小さいほど良いわけです．コレクタ容量 C_{ob} はコレクタ電圧の高い場合には小さくなり，この傾向は**図9**のようになります．

このコレクタ容量は正しくはコレクタ-ベース間の容量で，C_c の記号で表しますが，一般にはこれを外部から測った値として C_{ob} をコレクタ容量としています．C_{ob} にはトランジスタ動作をしていない部分の寄生素子の容量とか，ケースの浮遊容量も含んでいるので，最近のように C_c の小さい超高周波トランジスタでは上の式を C_{ob} で計算したのでは実際と合わない場合が多くなります．こんな時には是非とも C_c と $r_{bb'}$ または $C_c \cdot r_{bb'}$ 積の値が必要となります．

EIAJ登録では，高周波用トランジスタを登録する際には $r_{bb'}$ の代わりに $h_{ie(real)}$，つまりエミッタ接地高周波入力インピーダンスの実数分を書いてもよいようになっているので，本規格表では $h_{ie(real)}$ の時には $r_{bb'}$ 欄の値に＊印をつけました．また，$C_c \cdot r_{bb'}$ の時には $r_{bb'}$ の欄に $\underset{10\mathrm{ps}}{C_c \cdot r_{bb'}}$ のように書いてあります．

<図9> コレクタ容量の電圧特性例



11 トランジスタの外形

トランジスタの外形はよく似ているようでも，それぞれのメーカーのカタログをよく調べてみると少しずつちがっています．

これは，わが国の半導体技術が米国のそれの影響を強く受けて発展して来たとはいえ，各メーカーにおける社内事情に合わせて少しずつ変えたため，必ずしも同じ寸法値にならなかったためです．また，最近の樹脂封止（プラスチック・モールド）のパッケージでは設計の自由度が大きく，ユーザーの要求にこたえたいろいろな外形が実現できるようになり，しかもわが国独自の設計によるものがたくさん出て来ています．

これらのわずかなちがいを全部ちがった外形としてとり扱うと，この規格一覧表の半分以上のページを外形図でとられてしまいます．かといって筆者の判断で似ているものを統一した外形図面にしてしまうと，メーカーからお叱りをうけることになりましょう．

電子機械工業会（EIAJ）では，日本国内

で2社以上が使っている外形と，日本国内で使っているのは1社ですが，米国のJEDEC，または世界の標準であるIECに標準外形として決められているものを優先的にとり上げて，EIAJの標準外形を決めています．このEIAJ標準外形に合致するものをまとめれば，大部分のものがこれに吸収でき，それ以外の1メーカー独自のものをそれぞれの外形図で示すことにしました．

このため，個々の半導体メーカーのカタログの外形図と細部の寸法は異なることになりますが，カタログの外形図は必ずEIAJの標準外形図を満足していて，寸法的にはキツいようになっているはずです．

EIAJ標準外形ではケースとベースを分けて標準化しており，このそれぞれの組み合わせをあるていど自由にしてあります．その組み合わせは図中にケースはTC番号で，ベースはTB番号でEIAJの外形標準番号を記入しておきました．ケースとベースを分離しにくい外形の場合はSC番号を使うことになっています．また，外形図によっては，ほとんどの部分の寸法が同じで，ごく一部だけが異なるものがあり，これらを同じ外形番号として，そのあとのA，B，C等の文字で区分する方法をとりました．外形が全く同じで，電極接続が異なる場合も同様の方法で区分しています．

図面の書き方はすべて第三角法で，できるだけ，JISの製図法によっています．

電極接続はすべて図中にリード番号を入れて示しましたが，エミッタ，ベース，コレクタのどれかの電極がケースに内部で接続されている場合には，1メーカー独自の外形図では，コレクタ（ケース）のように示しましたが，EIAJ標準外形図の場合には示していないものがあるので，特にご注意ください．

12 備　考

この欄にはいろいろの事を書きました．これらには，次のようなものがあります．

(1) 現在のEIAJ名称が決まる前の旧型名，または試作名，あるいはEIAJ型名とは別にメーカー独自の型名がある場合．

(2) 特性規格に表現されにくい特別な特性
例　フォワードAGC，双方向性

(3) 特殊な組み合わせ複合素子
例　2素子複合，ツェナ・ダイオード組みこみ，ダンパ内蔵など

(4) コンプリメンタリ(相補対称)の品種を例えば 2SC828とコンプリ のように書いてあります．

(5) 規格一覧表左欄外の★印は，その品種が登録メーカーによって保守または廃品種に指定されていることを表しています．なお，EIAJへの登録制度では，登録が完了するとそのメーカー以外のメーカーがその型名と規格で生産，販売してもよいことになっています．したがって登録メーカーが保守または廃品種に指定してもその型名と規格はなくなったわけではなく，他のメーカーによって生産，販売される可能性は残っています．ただし，★印付きで空欄の品種は，型名の番号のみ予約されて規格が未登録または予約されていても該当メーカが不明のものです．したがって，将来，この型名のトランジスタは発表されません．

また，右欄○印の品種は巻末の追補版を参照して下さい．

規格一覧表

このページは空白です.

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE} V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SA 12	日立	IF	Ge. A	−16		−15	80	85	−6	−12				−6	1	60	PG = 31 dB (f = 455 kHz)			8	10	70	12A	2N218 HJ22D
★	〃 13	〃	〃	〃	−12		−15	80	85	−10	−12				−6	1	55	PG = 31 dB (f = 455 kHz)			8	10	70	12A	2N410 HJ 56
★	〃 14	〃	〃	〃	−16		−15	80	85	−6	−12				−6	1	50				4	10	90	12A	2S148 HJ 62
★	〃 15	〃	Conv	〃	−16		−15	80	85	−6	−12				−6	1	60	CG = 35 dB (f = 1.5 MHz)			12	10	70	12A	2N219 HJ23D
★	〃 16	〃	〃	〃	−12		−15	80	85	−10	−12				−6	1	60	CG = 35 dB (f = 1.5 MHz)			12	10	70	12A	2N412
★	〃 17	〃	Mix	〃	−12		−15	50	85	−6	−12				−6	1		CG = 20 dB (f = 12 MHz)			19	9.5	110	12A	2S146 HJ 60
★	〃 18	〃	RF	〃	−21		−15	80	85	−7	−23				−6	1					19	9.5	110	12A	2S148 HJ 62
★	〃 19	日電	IF	Ge.GD	−12		−2	15	55	−10	−9				−6	1	20	PG = 36 dB (f = 455 kHz)			50	1.5		19A	
★	〃 20	〃	〃	〃	−12		−2	15	55	−10	−9				−6	1	30	PG = 39 dB (f = 455 kHz)			55	1.5		19A	
★	〃 21	〃	〃	〃	−12		−2	15	55	−10	−9				−6	1	50	PG = 42 dB (f = 455 kHz)			55	1.5		19A	
★	〃 22	富士通	RF. IF	Ge. A	−20		−20	100	70	−5	−20				−6	1	-0.98*	30*	6*	0.4*	12	12	120	76	2S125
★	〃 23	〃	〃	〃	−20		−15	100	70	−5	−20				−6	1	-0.98*	30*	6*	0.4*	8	12	120	76	2S126
★	〃 24	〃	RF	Ge. D	−30		−10	60	70	−5	−6				−6	1	-0.975*	27*	1*	0.2*	100	3.5	150	61	
★	〃 25	〃	〃	〃	−25		−15	50	70	−5	−6				−6	1	-0.975*	27*	1*	0.2*	100	3.5	100	61	
★	〃 26	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. A	−20		−50	200	85	−12	−16				−6	1	60	30*	12	0.8	6	15	100	84A	ST20B ST20C
★	〃 27	東芝	Conv	Ge. D	−18		−5	55	75	−12	−18				−6	1					50	2	40	13A	2S60
★	〃 28	〃	RF	〃	−18		−5	55	75	−8	−12				−6	1	75	h_{fe} = 8～44 (f = 1.5 MHz)				2	40	13A	2S92
★	〃 29	〃	IF	〃	−18		−5	55	75	−12	−18				−6	1					35	2	35	13A	2S93
★	〃 30	富士通	Conv	Ge. A	−12		−10	80	85	−10	−12				−6	1	75	PG = 30 dB (f = 1.5 MHz)			10	10	85	12A	2NJ8A 2S30
★	〃 31	〃	IF	〃	−12		−10	80	85	−10	−12				−6	1	50	PG = 37 dB (f = 455 kHz)			5	10	75	12A	2NJ5A 2S31
★	〃 32	〃	RF. IF	〃	−20		−50	100	70	−5	−20				−6	1	-0.985*	29*		0.4*	10	12	150	78	
★	〃 33	〃	〃	〃	−20	−15R	−25	100	70	−5	−20				−6	1	-0.985	29*		0.4*	6	12	150	78	
★	〃 35	〃	Conv	〃	−16		−15	80	85	−6	−12				−6	1	75	2570	4.23	32.7	10	10	85	12A	2S35
★	〃 36	〃	IF	〃	−16		−15	80	85	−6	−12				−6	1	50	1520	3.16	24.6	5	10	75	12A	2S36
★	〃 37	東芝	Conv	〃	−18		−5	25	75	−10	−18				−6	1	-0.985*	CG = 32 dB (f = 1 MHz)			7	10.5	80	5	
★	〃 38	〃	IF	〃	−18		−5	25	75	−10	−18				−6	1	-0.985*	h_{fe} = 18 (f = 455 kHz)			10	10.5	80	5	
★	〃 39	〃	〃	〃	−18		−5	25	75	−10	−18				−6	1	-0.98*	h_{fe} = 9 (f = 455 kHz)			5.5	10.5	80	5	
★	〃 40	富士通	SW	〃	−25	−18R	−50	80	85	−6	−12				−6	1	65	t_r=0.3μs, t_f=0.2μs t_r=0.4μs			5	10	<75	12A	
★	〃 41	日立	RF	〃	−35		−40	250 (放熱板付)	70	−6	−12				−6	1	45				6	10	95	64	2S191 HJ 41
★	〃 42	〃	〃	〃	−45		−40	250 (放熱板付)	70	−6	−12				−6	1	45				6	10	95	64	2S192 HJ 42

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SA 43	富士通	RF	Ge. D	−35		−10	80	85	−10	−12				−9	1	60	PG = 24 dB (f = 10.7MHz)			40	2.3	40	13A	2S 43
★	〃 44	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. A	−15		−10	80	75	−10	−10				−6	1	100	CG = 28 dB (f = 1 MHz)			15	10.5	110	20	OC 44
★	〃 45	東芝	IF	〃	−18		−5	60	75	−12	−18				−6	1		h_{fe} = 5 (f = 455kHz)				11	80	12A	2S 45
★	〃 46	富士通	RF. IF	〃	−12		−25	100	70	−10	−12				−6	1	−0.985*	29*		0.4*	10	12	150	78	
★	〃 47	〃	〃	〃	−12		−25	100	70	−10	−12				−6	1	−0.985*	29*		0.4*	6	12	150	78	
★	〃 48	東芝	RF	〃	−18		−5	60	75	−12	−18				−6	1		h_{fe} = 14 (f = 1.5MHz)				11	80	12A	2S 48
★	〃 49	〃	IF	〃	−18		−5	60	75	−10	−18				−6	1	30~200	h_{fe} = 11~40 (f = 455kHz)				10.5	90	12A	2S 49
★	〃 50	〃	SW	〃	−18	−16S	−24	60	75	−3	−12	100	−1	−24	−6	1					14	10	<150	12A	2S 50
★	〃 51	〃	RF	〃	−18		−5	60	75	−10	−18				−6	1	−0.985*	PG = 36 dB (f = 1 MHz)			14	10.5	90	12A	2S 51
★	〃 52	〃	Conv	〃	−18		−5	60	75	−10	−18				−6	1	25~180	h_{fe} = 8~22 (f = 455kHz)				10.5	80	12A	2S 52
★	〃 53	〃	IF	〃	−18		−5	60	75	−10	−18				−6	1	20~140	h_{fe} = 5~17 (f = 455kHz)				10.5	90	12A	2S 53
★	〃 54	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. Me	−20	−15R	−5	75	85	−5	−12				−6	2	10	PG = 12 dB (f = 200MHz)			400*	1.5	40	59	
★	〃 55	松下	〃	Ge. A	−15		−10	80	75	−10	−10				−6	1	50				6	10.5	75	20	OC 45
★	〃 56	日電	SW	Ge. Me	−15	−15S	−50	150	100	−5	−5	40	−0.3	−10	−3	10		t_d=22ns, t_s=65ns t_r=28ns, t_f=45ns			300*	5		49C	
★	〃 57	東芝	RF	Ge. D	−18		−5	55	75	−10	−18				−6	1	20~350	PG = 16 dB (f = 50 MHz)			85	2	45	13A	2S 57
★	〃 58	〃	RF. Conv	〃	−18		−5	55	75	−10	−18				−6	1	20~350	PG = 24 dB (f = 20 MHz)			75	2	45	13A	2S 58
★	〃 59	〃	Conv	〃	−18		−5	55	75	−12	−18				−6	1	70	CG = 23 dB (f = 18 MHz)			65	2	40	13A	2S 59
★	〃 60	〃	〃	〃	−18		−5	55	75	−10	−18				−6	1	40~350	CG = 26 dB (f = 12 MHz)			55	2	40	13A	2S60A
★	〃 61	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. AD	−20		−10	100	75	−13	−6				−6	1	80				70	2	50	12A	
★	〃 64	富士通	SW	Ge. A	−16	−12R	−40	80	85	−6	−12				−6	1	65	t_r=0.2μs, t_f=1.5μs t_s=0.35μs			15	10	< 85	12A	2S 64
★	〃 65	東芝	〃	〃	−18	−18S	−200	150	75	−7	−12	80	−0.5	−100	−6	1		t_r=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.14μs			6	<16	<140	12A	
★	〃 66	〃	〃	〃	−18	−18S	−200	150	75	−7	−12	80	−0.5	−100	−6	1		t_r=0.085μs, t_f=0.085μs t_s=0.14μs			10	<16	<140	12A	
★	〃 67	〃	〃	〃	−18	−18S	−200	150	75	−7	−12	80	−0.5	−100	−6	1		t_r=0.06μs, t_f=0.06μs t_s=0.14μs			14	<16	<140	12A	
★	〃 68	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. AD	−20		−10	100	75	−13	−6				−6	1	80	g_{ie} 3 mS	y_{fe} 20 mS	g_{oe} 90 μS	70	Coe 5 pF		72A	
★	〃 69	〃	〃	〃	−20		−10	100	75	−13	−6				−6	1	80	g_{ie} 3 mS	y_{fe} 27 mS	g_{oe} 90 μS	70	Coe 5 pF		72A	OC169
★	〃 70	〃	〃	〃	−20		−10	100	75	−13	−6				−6	1	80	g_{ie} 2.5mS	y_{fe} 32 mS	g_{oe} 60 μS	70	2	50	72A	OC170
★	〃 71	〃	〃	〃	−20		−10	100	75	−13	−6				−6	1	80	g_{ie} 23 mS	y_{fe} 14 mS	g_{oe} 350μS	100	2	50	72A	OC171
★	〃 72	東芝	RF	Ge. D	−18		−5	55	75	−12	−18				−6	1	50	h_{fe} = 19 (f = 1.5MHz)			40	2	40	13A	
★	〃 73	〃	Conv	〃	−18		−5	55	75	−12	−18				−6	1	50	h_{fe} = 15 (f = 1.5MHz)			35	2	40	13A	
★	〃 74	〃	RF	〃	−50		−50	120	75	−8	−12				−9	1	70	2000	0.3	15	70	2.2	30	13A	

2SA

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SA 75	東芝	RF	Ge. D	−20		−50	120	75	−8	−12				−9	1	70	2000	0.3	15	30	2.2	30	13A	
★	〃 76	〃	〃	〃	−18		−5	55	75	−15	−18				−6	1	20～350	PG = 13 dB (f = 100MHz)			130	1.7	40	13A	
★	〃 77	〃	Osc	〃	−18		−5	55	75	−15	−18				−6	1	20～350	V_{OSC} = 100mV (f = 110.7MHz)			110	1.7	40	13A	
★	〃 78	〃	SW	〃	−40	−40S	−400	125	75	−8	−12	60	−1	−400	−6	1		t_r=0.085μs, t_f=0.25μs t_s=0.085μs			40	< 6	<120	13A	
★	〃 79	〃	〃	Ge. A	−20	−18S	−200	60	75	−7	−12	70	−0.5	−100	−6	1					> 4	< 15	<140	12A	
★	〃 80	日立	RF. Conv	Ge. D	−20		−10	80	85	−20	−12				−9	1	80	PG = 16 dB (f = 12 MHz)			60	1.7	35	13A	2S140 HJ 70
★	〃 81	〃	Osc	〃	−20		−10	80	85	−20	−12				−9	1	80				40	1.7	41	13A	2S141 HJ 71
★	〃 82	〃	Mix	〃	−20		−10	80	85	−8	−12				−9	1	6	CG = 24 dB (f = 12 MHz)			40	1.7	25	13A	2S142 HJ 72
★	〃 83	〃	IF	〃	−25		−10	80	85	−8	−12				−9	1	60	PG = 39 dB (f = 455kHz)			30	1.7	25	13A	2S143 HJ 73
★	〃 84	〃	Conv	〃	−25		−10	80	85	−8	−12				−9	1	60	CG = 41 dB (f = 1.5MHz)			35	1.7	35	13A	2S144 HJ 74
★	〃 85	〃	RF	〃	−25		−10	80	85	−8	−12				−9	1	60	PG = 31 dB (f = 1.5MHz)			55	1.7	30	13A	2S145 HJ 75
★	〃 86	〃	〃	〃	−45		−50	225 (放熱板付)	85	−12	−12				−9	1	80				35	1.7	45	67	2S190 HJ 76
★	〃 87	〃	〃	〃	−30		−10	80	85	−12	−12				−12	1.5	100				100	1.9	40	13A	
★	〃 88	〃	Osc	〃	−30		−10	80	85	−12	−12				−12	1.5	60				100	1.9	60	13A	
★	〃 89	〃	Mix	〃	−30		−10	80	85	−12	−12				−12	1.5	80				90	2.3	60	13A	
★	〃 90	〃	RF	〃	−30		−20	200 (放熱板付)	85	−12	−12				−12	1.5	>20				>60	< 3	60	67	
★	〃 92	東芝	Osc	〃	−18		−5	55	75	−10	−18				−6	1	40～350				50	1.9	40	13A	2S92A
★	〃 93	〃	Mix	〃	−18		−5	55	75	−10	−18				−6	1	20～350	CG = 25 dB (f = 12 MHz)			45	1.9	30	13A	2S93A
★	〃 94	日立	Conv	〃	−9		−10	80	85	−15	−9				−3	1					45	5	65	13A	
★	〃 95	富士通	RF	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1					50	2.3	50	72B	2S 95
★	〃 96	〃	〃	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1					45	2.3	50	72B	2S 96
★	〃 97	〃	〃	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1					40	2.3	50	72B	2S 97
★	〃 98	〃	Osc	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1					30	2.3	50	72B	2S 98
★	〃 99	〃	Mix	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1					20	2.3	50	72B	2S 99
★	〃 100	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−40		−10	60	75	−16	−10				−6	1	>80			1.5*	20	1.7	100	12C	
★	〃 101	〃	〃	〃	−40		−10	60	75	−16	−10				−6	1	>12			1.5*	15	1.7	30	12C	MC101
★	〃 102	〃	〃	〃	−40		−10	60	75	−16	−10				−6	1	40			1.5*	25	1.7	40	12C	MC102
★	〃 103	〃	〃	〃	−40		−10	60	75	−16	−10				−6	1	50			1.5*	35	1.7	50	12C	MC103
★	〃 104	〃	〃	〃	−40		−10	60	75	−16	−10				−6	1	100			1.7*	50	1.7	50	12C	MC104
★	〃 105	富士通	Conv	〃	−6		−10	80	85	−10	−6				−3	1	50	PG = 20 dB (f = 12 MHz)			75	3	50	13A	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SA106	富士通	Conv. Mix Osc	Ge. D	−6		−10	80	85	−10	−6				−3	1	50	PG = 28 dB (f = 1.5MHz)			30	3	50	13A	
★	〃 107	〃	IF	〃	−6		−10	80	85	−10	−6				−3	1	40	PG = 40 dB (f = 455kHz)			20	3	50	13A	
★	〃 108	〃	RF	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1	70	PG = 17 dB (f = 20MHz)			50	2.3	50	13A	2S108
★	〃 109	〃	〃	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1	60	PG = 15 dB (f = 20MHz)			45	2.3	50	13A	2S109
★	〃 110	〃	Conv	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1	60	PG = 20 dB (f = 12MHz)			40	2.3	50	13A	2S110
★	〃 111	〃	Osc	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1	40	Vosc = 0.4 V (f = 12MHz)			30	2.3	50	13A	2S111
★	〃 112	〃	Mix	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1	45	PG = 15 dB (f = 12MHz)			20	2.3	50	13A	2S112
★	〃 113	〃	Conv. Mix	〃	−34		−10	80	85	−7	−12				−12	1	45	CG = 40 dB (f = 1MHz)			20	2	50	13A	
★	〃 114	〃	IF	〃	−34		−10	80	85	−7	−12				−12	1	40	PG = 39 dB (f = 455kHz)			20	2	50	13A	
★	〃 115	〃	RF	〃	−34		−10	80	85	−5	−12				−12	1	60	PG = 28 dB (f = 1.5MHz)			30	2	50	13A	
★	〃 116	〃	〃	〃	−30		−10	80	85	−10	−12				−12	1.5	60	PG = 15 dB (f = 50MHz)			120	2	50	13A	
★	〃 117	〃	Osc	〃	−30		−10	80	85	−10	−12				−12	1.5	40	Vosc = 0.25V (f = 60.7MHz)			110	2	50	13A	
★	〃 118	〃	Mix	〃	−30		−10	80	85	−10	−12				−12	1.5	60	PG = 15 dB (f = 50MHz)			100	2	50	13A	
★	〃 121	ソニー	RF. Conv Mix. Osc	Ge. GD	−15	−15R	−2	15	65	−8	−15				−6	1	−0.96*	50*	5*	0.25*	100	1.3		18	2S173 2T201
★	〃 122	〃	〃	〃	−15	−15R	−2	15	65	−8	−15				−6	1	−0.96*	50*	5*	0.25*	100	1.3		18	2T201
★	〃 123	〃	〃	〃	−15	−15R	−2	15	65	−8	−15				−6	1	−0.96*	50*	5*	0.25*	100	1.3		18	2T201
★	〃 124	〃	〃	〃	−15	−15R	−2	15	65	−8	−15				−6	1	−0.97*	50*	5*	0.25*	120	1.3		18	2S138
★	〃 125	〃	〃	〃	−15	−15R	−2	15	65	−2	−15				−6	1	−0.98*	40*	5*	0.25*	120	1.3		18	2S139
★	〃 126	日電	SW	Ge. Me	−12	−12S	−50	150	100	−5	−5	40	−0.5	−10	−3	10		t_d = 22ns, t_s = 65ns t_r = 28ns, t_f = 45ns			300*		5	49C	
★	〃 127	東芝	RF	Ge. D	−70		−50	150	75	−50	−12				−6	1	−0.98*				25	15	40	13A	
★	〃 128	〃	SW	〃	−40	−40S	−600	170	75	−50	−12	35	−1.5	−600	−6	1		t_r = 0.35μs, t_f = 1.1μs t_s = 0.8μs			>15	<25	<70	13A	
★	〃 129	〃	〃	〃	−40	−40S	−600	170	75	−50	−12	70	−1.5	−600	−6	1		t_r = 0.35μs, t_f = 1.1μs t_s = 0.8μs			>15	<25	<70	13A	
★	〃 130	日立	RF. Conv	Ge. Me	−9		−10	80	85	−15	−9				−3	1	80	PG = 19 dB (f = 12MHz)			65	4	55	13A	
★	〃 131	〃	Osc	〃	−9		−10	80	85	−15	−9				−3	1	50				45	4	60	13A	
★	〃 132	〃	Mix	〃	−9		−10	80	85	−15	−9				−3	1	80	CG = 25 dB (f = 12MHz)			50	4	70	13A	
★	〃 133	〃	IF	〃	−9		−10	80	85	−15	−9				−3	1	60	PG = 39 dB (f = 455kHz)			40	4	110	13A	
★	〃 134	〃	〃	〃	−20		−10	80	85	−30	−20				−6	1					140	3	100	72A	
★	〃 135	〃	RF. Conv	〃	−20		−10	80	85	−30	−20				−6	1					150	3	80	72A	
★	〃 136	富士通	Conv	Ge. A	−6		−10	80	85	−10	−6				−3	1	75	CG = 25 dB (f = 1.5MHz)			10	13	85	12A	
★	〃 137	〃	IF	〃	−6		−10	80	85	−10	−6				−3	1	50	PG = 28 dB (f = 455kHz)			5	13	75	12A	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SA138	富士通	SW	Ge. A	−20		−200	175	85	−5	−20	70	−1	−10	−6	1		t_r=0.35μs, t_{stg}=0.2μs t_f=0.2μs			10			84B	
★	〃 139	〃	〃	〃	−30		−200	175	85	−5	−20	70	−1	−50	−6	1		t_r=0.35μs, t_{stg}=0.2μs t_f=0.2μs			8			84B	
★	〃 141	三菱	IF	〃	−15		−15	80	85	−5	−12				−6	1	70*	PG = 33 dB (f = 455kHz)			4	12	60	12A	TJ 41
★	〃 142	〃	Conv	〃	−15		−15	80	85	−5	−12				−6	1	70	CG = 28 dB (f = 1 MHz)			8	12	60	12A	TJ 42 ○
★	〃 143	〃	RF. Conv	〃	−15		−15	80	85	−5	−12				−6	1	70*	PG = 15dB (f = 1.5MHz)			15	12	60	12A	TJ 43
★	〃 144	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−15		−10	80	75	−10	−10				−6	1	100	CG = 28 dB (f = 1 MHz)			15	10.5	110	12B	OC 44
★	〃 145	〃	〃	〃	−15		−10	80	75	−10	−10				−6	1	50				6	10.5	75	12B	OC 45
★	〃 146	三菱	IF	Ge. D	−20		−10	60	85	−15	−12				−6	1	50	PG = 37 dB (f = 455kHz)			20	2.5	40	13B	TJ 46
★	〃 147	〃	Conv. Mix	〃	−20		−10	60	85	−15	−12				−6	1	70				30	2.5	40	13B	TJ 47
★	〃 148	〃	Conv	〃	−20		−10	60	85	−15	−12				−6	1	70	CG = 36 dB (f = 1 MHz)			40	2.5	45	13B	TJ 48
★	〃 149	〃	RF	〃	−20		−10	60	85	−15	−12				−6	1	70				50	2.5	50	13B	TJ 49
★	〃 151	日立	IF	Ge. A	−9		−15	80	85	−5	−6				−3	1					6	13.5	90	12A	
★	〃 152	〃	Conv	〃	−9		−15	80	85	−5	−6				−3	1					10	13.5	110	12A	
★	〃 153	日電	Mix	Ge. GD	−15		−4	20	65	−5	−9				−6	1	60	CG = 28 dB (f = 12 MHz)			60	1.3		19A	2S153 ST27B
★	〃 154	〃	IF	〃	−15		−4	20	65	−5	−9				−6	1	20	PG = 36 dB (f = 455kHz)			50	1.5		19A	2S154 ST28A
★	〃 155	〃	〃	〃	−15		−4	20	65	−5	−9				−6	1	30	PG = 39 dB (f = 455kHz)			55	1.5		19A	2S155 ST28B
★	〃 156	〃	〃	〃	−15		−4	20	65	−5	−9				−6	1	50	PG = 42 dB (f = 455kHz)			55	1.5		19A	2S156 ST28C
★	〃 157	〃	Osc	〃	−15		−4	20	65	−5	−9				−6	1	50	V_{osc}= 3 V (f = 18. 455MHz)			65	1.5		19A	2S157 ST29
★	〃 159	〃	Conv	Ge. GD	−15		−4	20	65	−5	−9				−6	1	50	CG = 36 dB (f = 1. 6 MHz)			55	1.5		19A	2S159 ST37E
★	〃 160	〃	〃	〃	−15		−4	20	65	−5	−9				−6	1	60	CG = 39 dB (f = 1. 6MHz)			55	1.5		19A	2S160
★	〃 161	ソニー	RF	Ge. Me	−20		−15	50	85	−5	−15				−6	2	−0.93*				400*	1.2	80	53	
★	〃 162	〃	〃	〃	−20		−15	50	85	−5	−15				−6	2	−0.96*				400*	1.2	80	53	
★	〃 163	〃	〃	〃	−20		−15	50	85	−5	−15				−6	2	−0.985*				400*	1.2	80	53	
★	〃 164	〃	Osc	〃	−20		−15	50	85	−5	−15				−6	2	−0.93*				400*	1.2	80	53	
★	〃 165	〃	〃	〃	−20		−15	50	85	−5	−15	24	−3	−1	−6	2	−0.96*	PG = 20 dB (f = 100MHz)			450*	1.7	80	53	
★	〃 166	〃	〃	〃	−20		−15	50	85	−5	−15				−6	2	−0.985*				400*	1.2	80	53	
★	〃 167	日電	RF	Ge. A	−20	−18R	−50	125	75	−8	−20				−6	1	70	28*	13*	0.8*	9	15	120	84A	2S167 ST20A
★	〃 168	〃	〃	〃	−20	−18R	−50	175	75	−8	−20				−6	1	70	28*	13*	0.8*	9	15	120	91	2S168 ST20AR
★	〃 168A	〃	〃	〃	−20	−18R	−50	175	75	−8	−20				−6	1	70	28*	13*	0.8*	9	15	120	91	
★	〃 169	〃	SW	〃	−20	−15R	−50	125	75	−8	−20	70	−1	−10	−6	1					15	11	250	84A	2S169 ST20E

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FF}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SA170	日電	SW	Ge. A	−20	−15R	−50	175	75	−8	−20	70	−1	−10	−6	1					15	11	250	91	2S170 ST20ER
★	〃 171	〃	〃	〃	−20	−15R	−50	125	75	−8	−20	60	−1	−10	−6	1					8	11	230	84 A	2S171
★	〃 172	〃	〃	〃	−20	−15R	−200	175	75	−8	−20	40	−0.35	−200	−6	1					8	11	230	91	2S172
★	〃 173	〃	〃	〃	−20	−15R	−50	125	75	−8	−20	60	−1	−10	−6	1					4	13	200	84 A	2S173
★	〃 174	〃	〃	〃	−20	−15R	−50	175	75	−8	−20	60	−1	−10	−6	1					4	13	200	91	2S174
★	〃 175	東芝	RF	Ge. D	−18		−5	55	75	−15	−18				−6	1	20～350	PG = 16 dB (f = 50 MHz)			85	2	40	13 A	2S175
★	〃 176	〃	〃	〃	−18		−5	55	75	−12	−18				−6	1					85	2.5	45	13 A	2S176
★	〃 178	〃	〃	〃	−18		−5	55	75	−12	−18				−6	1	h_{fe} = 13 (−1.5V, 1mA, f = 1.5MHz)					2	40	13 A	
★	〃 180	三洋	Conv	Ge. A	−15		−10	50	75	−10	−15				−6	1	−0.986*	28*	4.7*	0.3*	10	12	100	12 B	
★	〃 181	〃	IF	〃	−15		−10	50	75	−10	−15				−6	1	−0.979*	29*	2.8*	0.4*	5	12	80	12 B	
★	〃 182	〃	〃	〃	−15	−12	−10	50	75	−10	−15				−6	1	−0.964*	29*	2.9*	0.5*	5	12	80	12 B	
★	〃 183	〃	〃	〃	−15		−10	50	75	−10	−6				−6	1	−0.988*	28*	6*	0.5*	16	12	120	12 B	
★	〃 184	〃	〃	〃	−15		−10	50	75	−10	−6				−6	1	−0.95*	29*	2.4*	0.5*	3	12	70	12 B	
★	〃 188	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−12		−15	80	85	−10	−12				−6	1	70				10	10	150	12 A	
★	〃 189	〃	IF	〃	−12		−15	80	85	−10	−12				−6	1	70				6	10	100	12 A	
★	〃 190	沖	Mix	Ge. D	−20		−15	80	80	−20	−20				−6	1	60				40	2.6	60	13 A	
★	〃 191	〃	〃	〃	−20		−15	80	80	−20	−20				−6	1	25				20	2.6	50	13 A	
★	〃 192	〃	Conv	〃	−20		−15	80	80	−20	−20				−6	1					13	3.2	40	13 A	
★	〃 193	〃	〃	Ge. A	−15		−15	80	80	−12	−15				−6	1	50				13	10	100	12 A	
★	〃 194	〃	IF	〃	−15		−15	80	80	−12	−15				−6	1	40				7	10	90	12 A	
★	〃 195	〃	〃	〃	−15		−15	80	80	−12	−15				−6	1	30				4	10	75	12 A	
★	〃 196	〃	〃	〃	−15		−15	80	80	−12	−15				−6	1	25				2.5	10	60	12 A	
★	〃 197	三洋	〃	〃	−15		−10	50	75	−10	−15				−6	1		h_{fe} = 2.5 (f = 455kHz)				12	55	12 B	
★	〃 198	〃	〃	〃	−15		−5	30	75	−25	−15				−6	1		h_{fe} = 4～50 (f = 455kHz)				12	55	12 B	
★	〃 199	〃	RF	〃	−15		−5	30	75	−10	−15				−6	1		h_{fe} = 9 (f = 1.5 MHz)				11	95	12 B	
★	〃 200	〃	〃	〃	−15		−5	30	75	−10	−15				−6	1		h_{fe} = 9 (f = 1.5MHz)				11	95	12 B	
★	〃 201	〃	IF. Conv	〃	−15		−15	100	75	−10	−15				−6	1	50	CG = 32 dB (f = 1 MHz)			8	11	65	12 B	
★	〃 202	〃	〃	〃	−15		−15	100	75	−10	−15				−6	1	55	PG = 34 dB (f = 455k Hz)			12	11	70	12 B	
★	〃 203	〃	IF	〃	−15		−15	100	75	−10	−15				−6	1	30	PG = 30.5 dB (f = 455k Hz)			5	11	55	12 B	
★	〃 204	日電	RF	〃	−30	−10	−200	150	85	−6	−10	60	−1	−10	−6	1	65	28*	12*	0.9*	6	15	130	84 A	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SA205	日電	RF. SW	Ge. A	−30	−15	−200	200	85	−6	−15	40	−1	−10	−6	1	45	28*	9*	1.1*	5	15	110	84 A	
★	〃 206	〃	〃	〃	−30	−20	−200	200	85	−6	−20	55	−1	−10	−6	1	60	28*	10*	0.8*	7	15	120	84 A	
★	〃 207	〃	〃	〃	−30	−15	−200	200	85	−6	−15	65	−1	−10	−6	1	70	28	11*	0.8*	12	15	130	84 A	
★	〃 208	日立	SW	〃	−20	−15	−400	120	85	−5	−12	>15	−0.3	−200	−6	1					> 3	<25	<120	84 A	
★	〃 209	〃	SW	〃	−20	−15	−400	120	85	−5	−12	>30	−0.3	−200	−6	1					> 5	<25	<150	84 A	
★	〃 210	〃	〃	〃	−20	−15	−400	120	85	−5	−12	>45	−0.3	−200	−6	1					>10	<25	<200	84 A	
★	〃 211	〃	〃	〃	−18	−12	−100	120	85	−10	−12	>30	−0.3	−100	−6	1					> 4	<20	<150	84 A	
★	〃 212	〃	〃	〃	−25	−15	−100	120	85	−5	−12	>30	−0.3	−100	−6	1					> 4	<20	<150	84 A	
★	〃 213	日電	RF. Mix	Ge. GD	−15		−2	15	65	−5	−9				−6	1	25	PG = 7 dB (f = 100MHz)			140	1		19 A	
★	〃 214	〃	Conv. Osc	〃	−15		−2	15	65	−5	−9				−6	1	25	PG = 29.5 dB (f = 10 MHz)			140	1		19 A	
★	〃 215	〃	RF	〃	−15		−2	15	65	−5	−9				−6	1	40	PG = 24 dB (f = 10 MHz)			120	1		19 A	
★	〃 216	〃	〃	〃	−15		−2	15	65	−5	−9				−6	1	40	PG = 27 dB (f = 10 MHz)			120	1		19 A	
★	〃 218	三洋	RF. IF	Ge. D	−20		−10	50	75	−12	−15				−6	1	90	CG = 30 dB (f = 4.5MHz)			55	3	65	13 A	
★	〃 219	〃	RF	〃	−20		−15	70	75	−15	−15				−6	1	70	PG = 20 dB (f = 10.7 MHz)			55	3.5	35	12 B	
★	〃 220	〃	RF. Conv	〃	−20		−15	50	75	−15	−15				−6	1	150				60	3.5	35	12 B	
★	〃 221	〃	〃	〃	−20		−15	70	75	−15	−15				−6	1	80	CG = 23 dB (f = 12 MHz)			55	3.5	35	12 B	
★	〃 222	〃	〃	〃	−20		−15	70	75	−15	−15				−6	1	90	CG = 13 dB (f = 27 MHz)			60	3.5	35	12 B	
★	〃 223	〃	Osc	〃	−20		−15	70	75	−15	−15				−6	1	120				65	3.5	30	12 B	
★	〃 224	〃	RF	〃	−20		−10	50	75	−12	−15				−6	1	170	PG = 20 dB (f = 25 MHz)			90	2.5	65	13 A	
★	〃 225	〃	〃	〃	−20		−15	70	75	−15	−15				−6	1	80				55	3.5	35	12 B	
★	〃 226	〃	RF. Mix	〃	−15		−10	50	75	−12	−15				−6	1	70	PG = 20 dB (f = 20 MHz)			95	3	70	13 A	
★	〃 227	〃	RF	〃	−20		−10	50	75	−12	−15				−6	1					90	2	250	12B	
★	〃 228	〃	〃	〃	−80		−50	170	75	−50	−40				−6	1	50				35	3	40	13 A	
★	〃 229	東芝	〃	Ge. Me	−20		−5	75	85	−10	−12				−6	2	−0.9*	PG = 9.5 dB (f = 200MHz)			400*	1	60	48C	
★	〃 230	〃	〃	〃	−20		−5	75	85	−10	−12				−6	2	−0.9*	PG = 11.5 dB (f = 200MHz)			400*	1	50	48C	
★	〃 231	日立	RF	Ge. A	−40		−400	3 W (Tc=25°C)	70	−50	−40				−6	70	60	85	3.5	1	2.5	70	60	83	
★	〃 232	〃	〃	〃	−30		−400	3 W (Tc=25°C)	70	−50	−30				−6	70	90	130	4.5	1	4	70	60	83	
★	〃 233	〃	IF	Ge. Me	−20		−10	80	85	−30	−20				−6	1	70	PG = 38 dB (f = 455kHz)			100	2.1	60*	13 A	
★	〃 234	〃	〃	〃	−20		−10	80	85	−30	−20				−6	1	70	PG = 38 dB (f = 455kHz)			120	2.1	55*	13 A	
★	〃 235	〃	RF. Conv	〃	−20		−10	80	85	−30	−20				−6	1	90	CG = 13 dB (f = 100MHz)			135	2.1	50*	13 A	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$* h_{ie}(real) (Ω)	外形	備考
★	2SA236	東芝	IF	Ge. D	−18		−5	55	75	−12	−18				−6	1	−0.98*	h_{fe} = 16 (f = 1.5MHz)			35	1.7	35	13A	
★	〃 237	〃	〃	〃	−18		−5	55	75	−12	−12				−6	1	−0.98*	h_{fe} = 17 (f = 1.5MHz)			35	2.5	35	13A	
★	〃 238	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. Me	−25		−30	200	85	−8	−15				−6	5	30	NF < 6 dB (f = 70 MHz)			700	2.5	35	84C	
★	〃 239	東芝	RF	〃	−20		−5	75	85	−10	−12				−6	1	−0.91*	PG = 14 dB (f = 100MHz)			200*	1.5	30	48C	
★	〃 240	〃	RF. Conv Mix. Osc	Ge. EMe	−20		−5	75	85	−10	−12				−6	1	20*	PG = 19dB (f = 70MHz)			200*	1	25	48C	
★	〃 241	松下	〃	Ge. AD	−20		−5	50	75	−13	−10				−6	1	25				200*	1.5	70	72B	
★	〃 242	〃	〃	〃	−20		−5	50	75	−13	−10				−6	1		g_{ie} 16 mS	y_{fe} 15 mS	g_{oe} 300μS	250*	1.5	70	72B	
★	〃 243	〃	〃	〃	−20		−5	50	75	−13	−10				−6	1					300*	1.5	100	72B	
★	〃 243A	〃	〃	〃	−20		−5	80 (放熱板付)	75	−13	−10				−6	1	25				300*	1.5	100	72B	
★	〃 244	日電	RF. Conv. Mix Osc. PA	Ge. Me	−25	−20S	−30	200	85	−8	−15				−6	5	30	PG = 12.5dB (f = 100MHz)			600	3		84C	
★	〃 244A	〃	〃	〃	−25	−20S	−30	200	85	−4	−15				−6	5	30	PG = 16 dB (f = 70 MHz)			400*			84C	
★	〃 245	〃	〃	〃	−25	−20S	−30	200	85	−8	−15				−6	5	30	PG = 14.5dB (f = 100MHz)			700	2.5		84C	
★	〃 246	日立	PA	〃	−30	−25S	−30	100	85	−30	−30				−6	5	70				160	3	70*	13A	
★	〃 247	〃	SW	〃	−10	−10S	−30	100	85	−5	−10	125	−3	−20	−3	20					200	4	65	13A	
★	〃 248	東芝	〃	Ge. D	−40	−40S	−200	125	75	−8	−12	60	−1	−200	−6	1		t_r = 30 ns, t_f = 50ns t_s = 200ns			40		<120	13A	
★	〃 249	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−40		−10	110	75	−16	−10				−6	1	60				50	1.7	50	12A	
★	〃 250	〃	〃	〃	−100		−10	110	75	−16	−10				−6	1	100				50	1.7	50	12A	
★	〃 251	富士通	SW	Ge. MA	−15	−6	−50	50	80	−5	−6	50	−1	−15	−6	1					50	2.5	150	60	
★	〃 252	〃	〃	〃	−15	−6	−50	50	80	−5	−6	150	−1	−15	−6	1					80	2.5	150	60	
★	〃 253	〃	RF	Ge. Me	−20		−30	200	85	−8	−15				−5	10	30				450	2.5	50	84C	
★	〃 254	〃	Conv	Ge. A	−12		−10	55	85	−10	−12				−6	1	80	PG = 30 dB (f = 1.5MHz)			10	10	120	4	
★	〃 255	〃	IF	〃	−12		−10	55	85	−10	−12				−6	1	50	PG = 37 dB (f = 455k Hz)			5	10	100	4	
★	〃 256	〃	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. D	−20		−10	55	85	−10	−12				−6	1	75	PG = 17 dB (f = 20 M Hz)			60	2.2	30	4	
★	〃 257	〃	〃	〃	−20		−10	55	85	−10	−12				−6	1	60	PG = 20 dB (f = 12 M Hz)			50	2.2	50	4	
★	〃 258	〃	〃	〃	−20		−10	55	85	−10	−12				−6	1	45	Vosc = 0.4 V (f = 12 M Hz)			40	2.2	70	4	
★	〃 259	〃	〃	〃	−20		−10	55	85	−10	−12				−6	1	45	PG = 15 dB (f = 12 M Hz)			30	2.2	70	4	
★	〃 260	三洋	RF	Ge. Me	−20		−10	100	85	−15	−15				−6	2	12	CG = 17 dB (f = 100MHz)			300*	1.5	50	48C	
★	〃 261	〃	〃	〃	−20		−10	100	85	−15	−15				−6	2	15	PG = 15 dB (f = 100MHz)			300*	1.5	60	48C	
★	〃 262	〃	〃	〃	−20		−10	100	85	−15	−15				−6	2	15	CG = 12 dB (f = 200MHz)			450*	1.5	65	48C	
★	〃 263	〃	〃	〃	−20		−5	60	85	−15	−15				−6	2	15	PG = 10 dB (f = 200MHz)			500*	1.5	65	50C	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$* h_{ie}(real) (Ω)	外形	備考
★	2SA264	三洋	RF	Ge.Me	−20		−10	100	85	−15	−15				−6	2	15	PG = 10 dB (f = 200MHz)			450	1.5		50C	
★	〃 265	〃	〃	〃	−20		−10	100	85	−15	−15				−6	2	15	CG = 28 dB (f = 25 MHz)			300	1.5		50C	
★	〃 266	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. D	−20		−10	80	85	−10	−12				−6	1	75	PG = 17 dB (f = 20 MHz)			60	2.2	30	12A	
★	〃 267	〃	〃	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−6	1	60	CG = 20 dB (f = 12 MHz)			50	2.2	50	12A	
★	〃 268	〃	〃	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−6	1	45	Vosc = 0.4 V (f = 12.455 MHz)			40	2.2	70	12A	
★	〃 269	〃	〃	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−6	1	45	CG = 35 dB (f = 1 MHz)			30	2.2	70	12A	
★	〃 270	〃	Conv	〃	−9		−10	80	85	−10	−6				−3	1	75	CG = 20 dB (f = 12 MHz)			50	3	50	12A	
★	〃 271	〃	〃	〃	−9		−10	80	85	−10	−6				−3	1	60	CG = 28 dB (f = 1.5 MHz)			30	3	50	12A	
★	〃 272	〃	IF	〃	−9		−10	80	85	−10	−6				−3	1	45	PG = 40 dB (f = 455 kHz)			20	3	50	12A	
★	〃 273	〃	Conv	〃	−34		−10	80	85	−7	−12				−12	1	45	CG = 40 dB (f = 1 MHz)			40	2	50	12A	
★	〃 274	〃	IF	〃	−34		−10	80	85	−7	−12				−12	1	40	PG = 40 dB (f = 455 kHz)			30	2	50	12A	
★	〃 275	〃	RF	〃	−34		−10	80	85	−5	−12				−12	1	60	PG = 28 dB (f = 1.5 MHz)			45	2	50	12A	
★	〃 276	東芝	SW	Ge. Me	−15	−15S	−20	75	75	−5	−12	60	−0.5	−10	−6	2					210*	3.5		48C	
★	〃 277	〃	〃	Ge. A	−18	−16S	−40	65	75	−3	−12	50	−1	−24	−6	1					3.5 ~13			84A	
★	〃 278	〃	〃	〃	−18	−16S	−40	65	75	−3	−12	100	−1	−24	−6	1					>11			84A	
★	〃 279	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. AD	−30		−30	120	75	−6	−6				−2	10	200				150*	4	50	72A	
★	〃 280	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	−30		−30	120	75	−6	−6				−2	10	200				70	2	50	72A	
★	〃 281	〃	〃	〃	−50		−30	120	75	−6	−6				−2	10	200				100	2	50	72A	
★	〃 282	東芝	SW	Ge. A	−18	−18S	−200	150	75	−7	−12	80	−0.5	−100	−6	1		t_r = 0.6 μs, t_f = 0.35 μs t_s = 0.32 μs			6			84A	
★	〃 283	〃	〃	〃	−18	−18S	−200	150	75	−7	−12	80	−0.5	−100	−6	1		t_r = 0.4 μs, t_f = 0.2 μs t_s = 0.3 μs			10			84A	
★	〃 284	〃	〃	〃	−18	−18S	−200	150	75	−7	−12	80	−0.5	−100	−6	1		t_r = 0.3 μs, t_f = 0.2 μs t_s = 0.28 μs			14			84A	
★	〃 285	日電	Conv	Ge. D	−18		−5	50	75	−15	−18				−6	1	70	CG = 40 dB (f = 1.6 MHz)			40	2	40	13A	
★	〃 286	〃	Conv. Mix	〃	−18		−5	50	75	−15	−18				−6	1	70	CG = 30 dB (f = 12 MHz)			50	2	40	13A	
★	〃 287	〃	RF	〃	−18		−5	50	75	−15	−18				−6	1	70	PG = 29 dB (f = 10 MHz)			60	2	40	13A	
★	〃 288	日立	〃	Ge. Me	−20		−10	80	85	−30	−20				−6	3	20	PG = 18 dB (f = 100MHz)			330*	0.88	65	72C	
★	〃 289	〃	〃	〃	−20		−10	80	85	−30	−20				−6	3	20	PG = 20 dB (f = 100MHz)			350*	0.82	65	72C	
★	〃 290	〃	〃	〃	−20		−10	80	85	−30	−20				−6	3	20	PG = 21 dB (f = 100MHz)			370*	0.78	65	72C	
★	〃 291	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. MD	−20		−50	50	85	−5	−6				−6	4	40				100	1.5	40	60	
★	〃 293	〃	RF	〃	−15		−50	50	85	−5	−6				−6	4	40				300*	1.5	50	60	
★	〃 296	富士ゼネ	IF	Ge. A	−15		−15	80	85	−5	−12				−6	1	45				5	13	80	12B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$* $h_{ie(real)}$ (Ω)	外形	備考
★	2SA297	富士ゼネ	RF	Ge. A	−16		−15	80	85	−5	−12				−6	1	65				10	13	80	12B	
★	〃 298	〃	Conv. Mix Osc	Ge. D	−40		−10	80	85	−8	−12				−6	1	55				35	2.5	40	13B	
★	〃 299	三洋	RF. IF	Ge. A	−15		−10	50	75	−11	−6				−6	1	60	PG = 31 dB (f = 455 kHz)						12B	
★	〃 300	〃	〃	〃	−15		−10	50	75	−11	−6				−6	1	60	PG = 31 dB (f = 455 kHz)						12B	
★	〃 301	松下	SW	Ge. AD	−30	−30S	−30	120	75	−6	−6	125	−1	−10										72B	
★	〃 302	〃	〃	Ge. A	−20	−20S	−100	83	75	−3	−5	20	−0.7	−100										20	
★	〃 303	〃	〃	〃	−20	−20S	−100	83	75	−3	−5	50	−0.7	−100										20	
★	〃 304	東芝	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−18		−40	65	75	−4	−12				−6	1	70	PG = 38 dB (f = 455 kHz)			4.5	11	80	84A	
★	〃 305	〃	〃	〃	−18		−40	65	75	−4	−12				−6	1	70	PG = 36 dB (f = 1 MHz)			10	11	80	84A	
★	〃 306	富士ゼネ	〃	Ge. D	−40		−10	80	85	−8	−12				−6	1	65				55	2.3	50	13B	
★	〃 307	〃	〃	〃	−40		−10	80	85	−8	−12				−6	1	70				75	2.2	50	13B	
★	〃 308	松下	〃	Ge. AD	−20		−5	83	75	−13	−12	>20	−12	−1	−12	1	250				450*	0.5	35	72A	
★	〃 309	〃	〃	〃	−20		−5	83	75	−13	−12	>20	−12	−1	−12	1	250				600*	0.5	20	72A	
★	〃 310	〃	〃	〃	−32		−25	166	75	−13	−12	>20	−12	−1	−12	1	250				650*	0.7	60	72A	
★	〃 311	東芝	SW	Ge. D	−40	−40S	−400	150	75	−6	−12	65	−1	−400	−6	1		t_r=0.34μs, t_f=0.15μs t_s=0.18μs			50	3	40	84A	
★	〃 312	〃	〃	〃	−40	−40S	−400	150	75	−6	−12	40	−1	−200	−6	1		t_r=0.4μs, t_f=0.14μs t_s=0.18μs			50	3	40	84A	
★	〃 313	〃	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−18		−20	60	75	−6	−12				−6	1	60	h_{fe} = 15 (f = 1.5MHz)			40	2	40	84A	
★	〃 314	〃	〃	〃	−18		−20	60	75	−6	−12				−6	1	100	h_{fe} = 15 (f = 1.5MHz)			40	2	40	84A	
★	〃 315	〃	〃	〃	−18		−20	60	75	−6	−12				−6	1	110	h_{fe} = 22 (f = 1.5MHz)			55	2	40	84A	
★	〃 316	〃	〃	〃	−18		−20	60	75	−6	−12				−6	1	110	h_{fe} = 28 (f = 455 kHz)			75	2	40	84A	
★	〃 321	三洋	IF	〃	−20		−15	70	75	−15	−15				−6	1	70				30	2.5~4.5	30	12B	
★	〃 322	〃	〃	〃	−20		−15	70	75	−15	−15				−6	1	70	CG = 36 dB (f = 1 MHz)			35	2~5	30	12B	
★	〃 323	〃	Conv	〃	−20		−15	70	75	−15	−15				−6	1	80				40	1.5~5.5	30	12B	
★	〃 324	〃	RF. IF	〃	−20		−15	70	75	−15	−15				−6	1	70				55	3.5	35	12B	
★	〃 325	富士ゼネ	SW	Ge. A	−20	−15R	−80	80	85	−5	−12	60	−1	−80										12B	
★	〃 326	〃	〃	〃	−20	−15R	−80	80	85	−5	−12	60	−1	−80										12B	
★	〃 327	〃	〃	Ge. D	−40	−20R	−80	80	85	−5	−12	30	−1	−80										13B	
★	〃 328	三洋	IF	〃	−20		−10	50	75	−20	−9				−6	1	60					3		13B	
★	〃 329	〃	〃	〃	−20		−10	50	75	−15	−12				−6	1	13~550				5~6	1.5~6.5	<90	12B	
★	〃 330	〃	RF. IF	〃	−20		−10	50	75	−15	−12				−6	1	13~550					1.5~6.5		12B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$* h_{ie}(real) (Ω)	外形	備考
★	2SA331	三洋	Conv	Ge. D	−40		−50	120	75	−15	−15				−6	1	30~300				>40	2~5	50	12B	
★	〃 332	〃	〃	〃	−20		−10	50	75	−20	−9				−6	1	110				60	3	150	13B	
★	〃 333	〃	Osc	〃	−20		−10	50	75	−20	−9				−6	1	30				55	3	150	13B	
★	〃 334	〃	Mix	〃	−20		−10	50	75	−20	−9				−6	1	30				65	3	150	13B	
★	〃 336	日立	IF	〃	−9		−10	80	85	−15	−9				−3	1	70	PG = 38 dB (f = 455 kHz)			30	2.6	40	13A	
★	〃 337	〃	Conv	〃	−9		−10	80	85	−15	−9				−3	1	70	CG = 36 dB (f = 1.5MHz)			35	2.6	40	13A	
★	〃 338	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	〃	−20		−5	50	75	−16	−10				−6	1	30				15	2.5	15	4	
★	〃 339	〃	〃	〃	−20		−5	50	75	−16	−10				−6	1	50				30	2.5	20	4	
★	〃 340	〃	RF. Conv Mix. Osc	Ge. AD	−20		−10	63	75	−13	−6				−6	1	100				70	2	50	50C	
★	〃 341	〃	〃	〃	−20		−10	63	75	−13	−6				−6	1	100				70	2	50	50C	
★	〃 342	〃	〃	〃	−20		−10	63	75	−13	−6				−6	1	100				100	2	40	50C	
★	〃 343	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	−20		−5	86	75	−12	−10				−6	1	100	PG = 18 dB (f = 100MHz)			100*	1.5	50	72B	
★	〃 344	〃	〃	〃	−30		−30	120	75	−6	−6				−2	10	200				100	4	35	13B	
★	〃 345	三菱	RF	Ge. Me	−20		−10	60	85	−30					−6	1	30	PG = 18dB (f = 200MHz)			>250*	1.2	<100	48C	
★	〃 346	〃	〃	〃	−20		−10	60	85	−30					−6	1	30	PG = 20dB (f = 200MHz)			>250*	1.2	<100	48C	
★	〃 347	〃	〃	〃	−20		−10	60	85	−30					−6	1	30	PG = 21dB (f = 200MHz)			>250*	1.2	<100	48C	
★	〃 348	〃	〃	〃	−20		−10	60	85	−30					−6	1	10	PG = 15dB (f = 100MHz)			>200*	1.5	<120	48C	
★	〃 349	〃	〃	〃	−20		−10	60	85	−30					−6	1	10	PG = 15dB (f = 50MHz)			>100*	1.5	<120	48C	
★	〃 350	日立	RF. Conv Mix. Osc	Ge. D	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1	90	PG = 14 dB (f = 20 MHz)			40	2.5	30*	12A	
★	〃 351	〃	RF. Osc	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1	70	PG = 11dB (f = 12MHz)			40	2.5	30*	12A	
★	〃 352	〃	RF. Conv Mix	〃	−20		−10	80	85	−10	−12				−9	1	75	CG = 22.5dB (f = 12MHz)			40	2.5	30*	12A	
★	〃 353	〃	RF	〃	−25		−10	80	85	−10	−12				−9	1	70	PG = 39 dB (f = 455 kHz)			30	2.5	30*	12A	
★	〃 354	〃	Conv. Mix	〃	−25		−10	80	85	−10	−12				−9	1	70	CG = 40 dB (f = 1 MHz)			30	2.5	30*	12A	
★	〃 355	〃	RF	〃	−25		−10	80	85	−10	−12				−9	1	70	PG = 33 dB (f = 1.5MHz)			30	2.5	30*	12A	
★	〃 356	〃	〃	〃	−9		−10	80	85	−15	−9				−3	1	80	PG = 40 dB (f = 455 kHz)			25	2.8	30	12A	
★	〃 357	〃	Conv. Mix	〃	−9		−10	80	85	−15	−9				−3	1	70	CG = 40 dB (f = 1.5MHz)			30	1.8	30	12A	
★	〃 358	〃	RF	〃	−75		−50	225 (放熱板付)	85	−12	−12				−9	1	90				40	2.5	35*	64	
★	〃 359	三洋	〃	Ge. Me	−20		−20	270	85	−15	−20				−6	5	30				300*	3.5	75	84B	
★	〃 360	三菱	〃	Ge. DB	−20		−10	80	85	−30	−20				−6	1	70				110	2.3	85	13A	
★	〃 361	〃	RF. Conv Mix. Osc	〃	−20		−10	80	85	−30	−20				−6	1	70				125	2.3	80	13A	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SA362	三菱	PA	Ge. DB	−30	−25S	−30	100	85	−30	−30				−6	5	70				150*	3	70	13A	
★	〃 363	〃	SW	〃	−10	−10S	−30	100	85	−5	−10				−3	20	80							13A	
★	〃 364	〃	RF	〃	−9		−10	80	85	−30	−9				−3	1	60				45	6	100	13A	
★	〃 365	〃	Mix. Osc	〃	−9		−10	80	85	−30	−9				−3	1	60				50	6	70	13A	
★	〃 366	〃	RF. Conv	〃	−9		−10	80	85	−30	−9				−3	1	60				75	6	50	13A	
★	〃 367	〃	RF	Ge. D	−20		−10	80	85	−15	−12				−9	1	70				30	2.5	40	12A	
★	〃 368	〃	Conv. Mix Osc	〃	−20		−10	80	85	−15	−12				−9	1	70				40	2.5	30	12A	
★	〃 369	〃	RF	〃	−20		−10	80	85	−15	−12				−9	1	80				50	2.5	30	12A	
★	〃 370	〃	〃	〃	−75		−50	120	85	−12	−12				−9	1	70				40	2.5	40	64	
★	〃 371	〃	SW	Ge. A	−20	−15	−15	80	85	−6	−12	70	−1.5	−10							10.5*	10	110	12A	
★	〃 372	東芝	〃	Ge. EMe	−15		−200	100	75	−10	−12	25	−1	−10	−3	5		t_d+t_r=6ns, t_f=15ns t_s=30ns			450*	2	120	49C	
★	〃 373	日立	RF	〃	−25	−12	−150	250	85	−15	−10				−10	5	40				400*	3.2	100	84A	
★	〃 373A	〃	〃	〃	−25		−150	250	85	−15	−10				−10	5	40				400*	3.2	100	84A	
★	〃 374	松下	RF. Conv. Mix Osc. PA	Ge. AD	−34		−300	1.5W (Tc=25°C)	90	−12	−10				−2	150	100				300*	13	10	84A	
★	〃 375	三菱	RF. Conv. Mix Osc. SW	Ge. D	−30	−30S	−100	80	85	−6	−12	40	−1	−50	−9	1	80				40	2.5	30	12A	
★	〃 376	ソニー	RF. Conv Mix.	Ge. DB	−22		−10	60	85	−6	−10	48	−3	−1	−6	2	0.96*	h_{fe} = 16dB (f = 100MHz)				0.4	70*	52	
★	〃 377	松下	RF. Conv. Mix Osc	Ge. AD	−20		−5	50	75	−13	−10				−6	1	100				200*	1.5	60	50C	
★	〃 378	〃	〃	〃	−20		−5	50	75	−13	−10				−6	1	100				250*	1.5	30	50C	
★	〃 379	〃	〃	〃	−20		−5	50	75	−13	−10				−6	1	100				300*	1.5	30	50C	
★	〃 380	富士ゼネ	RF. Conv	Ge. D	−25		−10	80	85	−12	−12				−6	1	70				60	2.2	40	12A	
★	〃 381	〃	Osc	〃	−25		−10	80	85	−12	−12				−6	1	50				35	2.5	40	12A	
★	〃 382	〃	Mix	〃	−25		−10	80	85	−12	−12				−6	1	55				30	2.2	40	12A	
★	〃 383	〃	RF	〃	−25		−10	80	85	−12	−12				−6	1	40				25	2.5	40	12A	
★	〃 384	〃	Conv	〃	−25		−10	80	85	−12	−12				−6	1	60				40	2.5	40	12A	
★	〃 385	松下	RF	Ge. A	−16		−10	80	75	−12	−10				−6	1	120				10	8	120	12A	
★	〃 386	〃	RF. Conv. Mix Osc	Ge. AD	−32		−300	1.85W (Tc=25°C)	90	−12	−10				−2	100	80				350*	12	8	84B	
★	〃 387	三洋	〃	Ge. A	−10		−15	100	85	−50	−10				−6	1	30	h_{fe} = 9 (f = 455kHz)				10	50	12B	
★	〃 388																								
★	〃 389	日立	RF	Ge. Me	−20	−15	−10	50	85	−30	−20				−10	2	30	PG = 8.5dB (f = 800MHz)			600*	0.4	$C_c r_{bb'}$ 10 ps	50C	
★	〃 390	〃	〃	〃	−20	−15	−10	50	85	−30	−20				−10	2	30	PG = 9.5dB (f = 800MHz)			700*	0.4	$C_c r_{bb'}$ 9.5ps	50C	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SA391	沖	RF	Ge. A	−18		−200	150	85	−6	−6				−5	1	70				7	10	150	84 B	
★	〃 392	〃	〃	〃	−18		−200	150	85	−6	−6				−5	1	100				11	9.5	175	84 B	
★	〃 393	〃	〃	〃	−18		−200	150	85	−6	−6				−5	1	150				16	9.2	200	84 B	
★	〃 393A	〃	〃	〃	−30		−200	150	85	−6	−6				−5	1	150				16	9.2	230	84 B	
★	〃 394	〃	〃	〃	−18		−200	150	85	−6	−6				−5	1	200				22	8.7	230	84 B	
★	〃 395	〃	〃	〃	−18		−200	150	85	−6	−6				−5	1	300				29	8.5	260	84 B	
★	〃 396	〃	〃	〃	−15		−200	200	85	−10	−12				−5	1	85				6	20	150	84 B	
★	〃 397	〃	〃	〃	−23		−200	200	85	−10	−12				−5	1	100				8	20	150	84 B	
★	〃 398	〃	〃	〃	−30		−200	200	85	−10	−12				−5	1	120				10	19	160	84 B	
★	〃 399	〃	〃	〃	−30		−200	200	85	−10	−12				−5	1	70				12	17	160	84 B	
★	〃 400	富士通	RF. Conv. Mix Osc	Ge. D	−20		−10	80	85	−10	−12				−6	1	70				70	2.3	50	13 A	
★	〃 401	日立	RF	Ge. Me	−30	−25S	−40	130	85	−30	−30				−6	5	70				30	3	70	13 A	
★	〃 402	東芝	〃	Si. EP	−35	−30	−100	250	175	−1	−15	200	−6	−2	−6	1					200*	6	30	49C	
★	〃 403	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. Me	−20	−15R	−5	75	85	−10	−12				−6	2	10	PG = 16 dB (f = 70 MHz)			280*	1.5	40	19 B	
★	〃 404	〃	〃	〃	−20	−15R	−5	75	85	−10	−12				−6	2	10	PG = 12 dB (f = 200MHz)			400*	1.5	40	59	
★	〃 405	〃	SW	〃	−15	−15S	−50	150	100	−3	−5	40	−0.5	−10	−3	10		t_d = 22 ns, t_s = 65 ns t_r = 28 ns, t_f = 45 ns			300*	5		49 C	
★	〃 406	〃	〃	Ge. A	−30	−15	−200	200	85	−7	−15	50	−1	−10	−6	1	60	28*	10*	0.8*	9	15	120	84 A	
★	〃 407	〃	〃	〃	−30	−12	−200	200	85	−7	−12	60	−1	−10	−6	1	70	28*	11*	0.8*	14	15	130	84 A	
★	〃 408	富士通	〃	Ge. MA	−15	−6	−50	50	80	−5	−6	100	−1	−15	−6	1					50	3		60	
★	〃 409	〃	〃	〃	−15	−6	−50	50	80	−5	−6	100	−1	−15	−6	1					80	3		60	
★	〃 410	日電	〃	Ge. EMe	−12	−12S	−150	150	100	−5	−5	40	−0.3	−10	−3	10		t_d = 10 ns, t_s = 50 ns t_r = 15 ns, t_f = 40 ns			300	1.5		49 C	
★	〃 411	〃	〃	〃	−15	−15S	−150	150	100	−5	−5	40	−0.3	−10	−3	10		t_d = 10 ns, t_s = 40 ns t_r = 15 ns, t_f = 35 ns			300	1.5		49 C	
★	〃 412	日立	〃	Ge. Me	−13	−12S	−100	150	85	−3	−6	50	−0.5	−30	−3	10					40*	7		12 A	
★	〃 413	松下	〃	Ge. AD	−20	−15S	−30	100	75	−5	−5	90	−1	−30	−2	30					>300*	4		49 C	
★	〃 414	〃	〃	Ge. A	−30	−25X	−200	150	85	−3	−5	40	−0.5	−100	−5	3					7*	9		84 A	
★	〃 415	〃	〃	〃	−25	−20X	−200	150	85	−3	−5	60	−0.5	−100	−5	3					10*	9		84 A	
★	〃 416	〃	〃	Ge. AD	−70	−60X	−700	6 W (T_c=25°C)	75	−1mA	−60	100	−10	−600	−10	300					120*	35		102	
★	〃 417	日電	〃	Ge. EMe	−15	−15S	−200	150	100	−5	−10	70	−0.3	−10				$t_d + t_r$ < 70ns, $t_s + t_f$ < 100ns t_s < 50ns						315	
★	〃 419	三洋	〃	Ge. Me	−20		−5	50	85	−10	−12				−6	2	20	PG = 12 dB (f = 200MHz)						50 C	
★	〃 420	〃	〃	〃	−20		−5	50	85	−10	−12				−6	2	25	PG = 12 dB (f = 200MHz)			550	2		50 C	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SA421	三洋	SW	Ge. Me	−20		−5	50	85	−10	−12				−12	2	25	PG = 8.5dB (f = 800MHz)						50C		
★	〃 422	〃	RF	〃	−20		−5	50	85	−10	−12				−12	2	25	PG = 10dB (f = 800MHz)			800	0.8		50C		
★	〃 423	〃	〃	Ge.EMe	−20		−5	50	85	−10	−12				−12	2	25	PG = 8.5dB (f = 800MHz)						50C		
★	〃 424	〃	〃	〃	−20		−5	50	85	−10	−12				−12	2	25	PG = 10dB (f = 800MHz)						50C		
★	〃 425	富士ゼネ	〃	Ge. Me	−30		−30	200	85	−10	−15				−6	2	25				350*	3.3	60*	84B		
★	〃 426	〃	〃	〃	−30		−30	200	85	−10	−15				−6	2	30				500*	2.5	60*	84B		
★	〃 427	三洋	〃	Ge. D	−20		−15	100	75	−15	−15				−6	1	60				45	3.5	40	13B		
★	〃 428	〃	〃	〃	−20		−15	100	75	−15	−15				−6	1	80				50	3.5	30	13B		
	〃 429	東芝	SW	Si. T	−150	−150	−30	400	125	−0.1	−150	70~240	−3	−10	−10	2					100*	3	50	138	2SC780Aとコンプリ	
★	〃 430	〃	RF	Ge. Me	−20		−5	70	85	−10	−12				6	1	−0.95*	PG = 10dB (f = 800MHz)			>450*	<0.8	<60	50C		
★	〃 431	〃	〃	〃	−20		−5	70	85	−10	−12				−6	1	−0.94*	PG = 16dB (f = 200MHz)						50C		○
★	〃 432	〃	〃	〃	−20		−5	70	85	−10	−12				−6	1	−0.94*	PG = 14dB (f = 200MHz)						50C		○
★	〃 433	〃	〃	Ge. D	−18		−5	55	75	−8	−12				−6	1	50	PG = 21dB (f = 10.7MHz)				<3.5		13A		
★	〃 434	日立	RF.Conv.Mix Osc	Ge. Me	−20		−10	80	85	−30	−20				−6	8	80	PG = 16.5dB (f = 100MHz)			880*	0.9	80	72A		
★	〃 435	〃	〃	〃	−20		−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 16.5dB (f = 100MHz)			330*	0.9	80	9		
★	〃 436	〃	〃	〃	−20		−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 18.5dB (f = 100MHz)			400*	0.98	65	9		
★	〃 437	〃	〃	〃	−20		−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 19.3dB (f = 100MHz)			400*	0.92	65	9		
★	〃 438	〃	〃	〃	−20		−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 20dB (f = 100MHz)			520*	0.88	65	9		
★	〃 439	三洋																								
★	〃 440	〃	RF.Conv.Mix Osc	Ge. Me	−20		−5	60	85	−30	−20				−6	2	50	PG = 14dB (f = 100MHz)			350*	1.5	70*	48C		○
★	〃 441	〃	〃	〃	−20		−10	150	85	−30	−20				−6	2	40				500*	3.5	70	84B		
★	〃 442	〃																								
★	〃 443	日立	Ch	Ge. A	−21	−12	−15	60	85	−6	−12	200	−6	−2	−6	1		h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0			25	10	70	15	2素子複合	
★	〃 444	〃		〃	−16	−13	−12	60	85	−6	−12	80	−6	−1	−6	1	80	ツエナダイオードを封入			12	7	70	14	ツエナ封入	
★	〃 445	〃	差動増幅	〃	−16	−13	−15	60	85	−6	−12	75	−6	−1	−6	1		h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0			10	10	70	15	2素子複合	
★	〃 446	東芝	SW	Ge.EMe	−15	−15S	−200	200	85	−10	−12	70	−1	−100				t_d+t_r<35ns, t_s+t_f<170ns t_s<140ns						84B		
★	〃 447	松下	RF.Conv.Mix Osc	Ge. AD	−25		−15	90	75	−3.5	−10				−10	2	80				650*	1.6	20	57		
★	〃 448	ソニー	RF.Conv	Ge. Me	−15		−5	40	75	−10	−10	20	−3	−3	−3	3	30	PG = 8dB (f = 1000MHz)			1700*	0.15		52		
★	〃 449	日立	SW	Ge.EMe	−10	−10S	−100	150	100	−5	−6	30	−1	−50	−1	20		t_d+t_r<80ns, t_s+t_f<120ns t_s<100ns			300*	4		49C		
★	〃 450	〃	〃	〃	−12		−100	150	100	−3	−6	40	−1	−50	−1	20		t_d+t_r<60ns, t_s+t_f<95ns t_s<80ns			500*	2.5		49C		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SA451	日立	SW	Ge.EMe	−12	−10S	−100	150	100	−3	−6	70	−1	−50	−1	20		t_d+t_r<60ns, t_s<90ns	t_s+t_f<110ns	500*	2.5		49C	
★	〃 452	〃	〃	〃	−12	−10S	−100	150	100	−3	−6	150	−1	−50	−1	20		t_d+t_r<60ns, t_s<100ns	t_s+t_f<120ns	500*	2.5		49C	
★	〃 453	ソニー	RF.Conv.Mix Osc	Ge. DB	−22		−10	60	85	−5	−15	6	−3	−1	−6	2	−0.93*	PG = 25dB (f = 100MHz)		630*	0.45	70*	52	
★	〃 454	〃	〃	〃	−22		−10	60	85	−5	−15	12	−3	−1	−6	2	−0.96*	PG = 25dB (f = 100MHz)		630*	0.45	70*	52	
★	〃 455	〃	〃	〃	−22		−10	60	85	−5	−15	24	−3	−1	−6	2	-0.978*	PG = 25dB (f = 100MHz)		630*	0.45	70*	52	
★	〃 456	〃	〃	〃	−22		−10	60	85	−5	−15	48	−3	−1	−6	2	-0.988*	PG = 25dB (f = 100MHz)		630*	0.45	70*	52	
★	〃 457	東芝	RF	Ge. D	−18		−20	55	75	−10	−12				−6	1	200	h_{fe}>18 (f = 1.5MHz)		45	3	150	13A	
★	〃 458	三菱	SW	Ge. A	−25	−20R	−200	150	85	−5	−12	60	−1	−10				t_d+t_r<1μs, t_s<0.7μs	t_s+t_f<0.7μs				69	2SC405とコンプリ
★	〃 459	〃	〃	〃	−25	−20R	−200	150	85	−5	−12	120	−1	−10				t_d+t_r<1μs, t_s<0.7μs	t_s+t_f<0.7μs				69	2SC406とコンプリ
★	〃 460	〃	RF. Osc	Ge.Me	−20	−20S	−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 17dB (f = 100MHz)		400*	0.9	80*	11A	
★	〃 461	〃	RF.Mix.Osc	〃	−20	−20S	−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 18dB (f = 100MHz)		400*	0.9	65*	11A	
★	〃 462	〃	RF	〃	−20	−20S	−10	60	85	−30	−20				−6	3	30	PG = 20dB (f = 100MHz)		400*	0.9	65*	11A	
★	〃 463	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	−20	−20S	−10	75	85	−30	−20				−6	3	10	PG = 16.5dB (f = 100MHz)		300*	1	80*	11A	
★	〃 464	〃	〃	〃	−15	−10	−10	60	85	−10	−15				−6	3	30			850*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 12ps	11A	
★	〃 465	松下	RF.Conv.Mix Osc	Ge.AD	−20		−5	50	75	−13	−10				−10	1	250	PG = 8 dB (f = 800MHz)		600*	0.5	20	57	
★	〃 466	東芝	RF.Conv.Mix Osc	Ge. D	−18		−10	55	85	−12	−18				−6	1	40			15*	3	50	12A	
	〃 467	〃	RF	Si. E	−40	−30	−400	400	125	−0.1	−40	70~240	−1	−100	−10	10				>100*	10	50	138	2SC367とコンプリ
★	〃 468	〃	RF.Conv.Mix Osc	Ge. D	−18		−10	55	85	−12	−18				−6	1	70			30*	3	40	12A	
★	〃 469	〃	〃	〃	−18		−10	55	85	−12	−18				−6	1	50			30*	3	40	12A	
★	〃 470	〃	〃	〃	−18		−10	55	85	−12	−18				−6	1	75			30*	3	40	12A	
★	〃 471	〃	〃	〃	−18		−10	55	85	−12	−18				−6	1	50	PG = 21dB (f = 10.7MHz)			<3.5		12A	
★	〃 472	〃	〃	〃	−18		−10	55	85	−12	−18				−6	1	80			30*	3	40	12A	
	〃 473	〃	PA	Si. E	−30	−30	−3A	10W (T_c=25°C)	150	−1	−20	70~240	−2	−500	−2	500				100*	40		268	2SC1173とコンプリ
★	〃 474	〃	RF.Conv.Mix Osc	Ge. D	−50		−50	120	85	−12	−12				−6	1	50			70	4	30	12A	
★	〃 475	〃	〃	〃	−20		−50	120	85	−12	−12				−6	1	50			30	4	30	12A	
★	〃 476	〃	〃	〃	−18		−10	55	85	−12	−18				−6	1	60			65	1.5	40	12A	
★	〃 477	〃	RF	〃	−18		−10	55	85	−12	−18				−6	1	60	PG = 27dB (f = 10.7MHz)			1.5		12A	
★	〃 478	〃	SW	〃	−40	−40S	−400	125	85	−8	−12	60	−1	−400	−6	1		t_r<85ns, t_s<85ns	t_f<250ns	>25	<6	<120	12A	
★	〃 479	〃	〃	〃	−40	−40S	−200	125	85	−8	−12	50	−1	−200	−6	1		t_r<50ns, t_s<300ns	t_f<70ns	>25	3	<120	12A	
★	〃 480	ソニー	RF	Si. E	−30	−20	−100	150	150	−3	−25	60	−3	−3	−6	1	120	h_{fe} = 3.0dB (f = 100MHz)			3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	60	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SA481	東芝																							
★	〃 482	〃	PA	Si. EP	−40	−32	−600	600	150	−1	−30	50	−2	−150	−10	10	50				70*	20	10	84B	
★	〃 483	〃	RF. AF. PA	Si.TMe	−150	−150	−1.5A	20 W (Tc=25°C)	150	−100	−150	30~240	−10	−100	−10	100					10*	50	25	99	
★	〃 484	〃	PA	Si. E	−110	−110	−1.5A	800	175	−10	−30	80	−2	−200	−10	30					20*	60	10	84B	2SC484 とコンプリ
★	〃 485	〃	〃	〃	−80	−80	−1.5A	800	175	−10	−30	80	−2	−200	−10	30					20*	60	10	84B	
★	〃 486	〃	〃	〃	−50	−50	−1.5A	800	175	−10	−30	80	−2	−200	−10	30					20*	60	10	84B	2SC486 とコンプリ
★	〃 487	〃																							
★	〃 488	〃																							
★	〃 489	〃	RF. PA	Si. EMe	−70	−60	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−30	−50	40~240	−5	−500	−5	500					>3*	230	15	268	
	〃 490	〃	PA	〃	−50	−40	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−30	40~240	−2	−500	−2	500					10*	150		268	2SC790 とコンプリ
★	〃 491	〃																							
★	〃 492	〃																							
	〃 493	〃	LN	Si. E	−50	−50	−150	400	125	−0.1	−50	120~400	−6	−2	−10	1	NF< 2 dB (6V, 0.1mA, 100Hz)				80*	6		138	2SC1000 とコンプリ
★	〃 494	〃	〃	〃	−35	−30	−30	200	125	−0.5	−15	70~400	−6	−0.1	−6	0.1	NF=2dB (f=120Hz)	10kΩ	1	3	200*	4	30	33	
	〃 495	〃	RF. SW	〃	−50	−50	−150	400	125	−0.1	−50	70~240	−1	−10	−10	10					200*	5	30	138	2SC372 とコンプリ
★	〃 496	〃	PA	〃	−40	−30	−1A	1W	150	−1	−30	40~240	−2	−50	−10	10					100*	20		342	2SC496 とコンプリ
	〃 497	〃	〃	〃	−80	−80	−800	600	150	−1	−30	40~240	−2	−200	−10	10					70*	33		84B	2SC497 とコンプリ
	〃 498	〃	〃	〃	−50	−50	−800	600	150	−1	−30	40~240	−2	−200	−10	10					70*	33		84B	2SC498 とコンプリ
	〃 499	〃	RF. SW	Si. E	−50	−40	−100	250	175	−0.5	−15	60~200	−1	−10	−10	10					250*	5	30	49C	2SC979 とコンプリ
	〃 500	〃	〃	〃	−30	−20	−100	250	175	−0.5	−15	60~200		−10	−10	10					250*	5	30	49C	2SC400 とコンプリ
★	〃 501	〃	〃	Si. EP	−40	−30	−200	750	175	−1	−30	70	−1	−10	−10	10					200*	10	30	84B	2SC501 とコンプリ
★	〃 502	〃	〃	〃	−90	−80	−100	300	125	−0.1	−70	40~240	−1	−120	−10	10					>50	8	50	33	
	〃 503	〃	〃	Si. E	−100	−80	−600	800	175	−0.5	−80	30~300	−2	−150	−10	10					80*	22	12	84B	2SC503 とコンプリ
	〃 504	〃	〃	〃	−80	−60	−600	800	175	−0.5	−60	30~300	−2	−150	−10	10					80*	22	12	84B	2SC504 とコンプリ
★	〃 505	〃	PA	〃	−60	−50	−800	600	125	−1	−30	40~240	−2	−50	−10	10					100*	20	10	342	2SC495 とコンプリ
★	〃 506	〃	RF.Conv.Mix Osc	Ge.EMe	−20		−5	75	85	−10	−12				−6	1	20				300*	1	25	10	
★	〃 507	〃	〃	〃	−20		−5	75	85	−10	−12				−6	1	20				250*	1	25	10	
★	〃 508	〃	〃	〃	−20		−5	75	85	−10	−12				−6	1	8				200*	1	25	10	
	〃 509	〃	PA. SW	Si. E	−35	−30	−800	600	150	−0.1	−35	70~240	−2	−50	−10	10					140*	22		138	2SC509 とコンプリ
	〃 510	〃	〃	〃	−120	−100	−1.5A	800	175	−1	−30	30~150	−2	−200	−10	30					60*	43		84B	2SC510 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SA511	東芝	PA	Si.TP	−90	−80	−1A	800	150	−1	−30				−10	50	50				50*	43	10	84B	2SC511とコンプリ
	〃 512	〃	PA.SW	Si.E	−80	−60	−1.5A	800	175	−1	−30	30~150	−2	−200	−10	30					60*	43		84B	2SC512とコンプリ
★	〃 513	〃	〃	〃	−50	−40	−1A	800	150	−1	−30				−10	50	50				50*	43	10	84B	2SC513とコンプリ
★	〃 514	〃																							
★	〃 515	〃																							
★	〃 516	〃	RF.PA	Si.DB	−80	−60	−1.5A	800	175	−0.5	−30	60	−2	−200	−5	200	60				50*	43	10	84B	
★	〃 516A	〃	〃	〃	−120	−100	−1.5A	800	175	−0.5	−30	60	−2	−200	−5	200	60				50*	43	10	84B	
★	〃 517	〃	RF	Ge.D	−18		−10	55	85	−12	−18				−6	1	60				60	1.8	45	12A	
★	〃 518	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	−18		−10	55	85	−12	−18				−6	1	60				45	1.8	45	12A	
★	〃 519	〃																							
★	〃 520	〃																							
★	〃 521	三洋																							
★	〃 522	東芝 富士通	RF	Si.EP	−25	−20	−100	250	175	−0.1	−15	30~120	−1	−10	−10	10	50				200*	4	25	49C	
★	〃 522A	〃	〃	〃	−50	−40	−100	250	175	−0.1	−15	30~120	−1	−10	−10	10	50				200*	4	25	49C	
	〃 523	富士通	RF.PA	〃	−40		−300	650	175	−0.1	−10	30~120	−10	−10	−10	10	60				200*	4.5	50*	84B	
	〃 523A	〃	〃	〃	−60	−40	−300	650	175	−0.1	−10	30~120	−10	−10	−10	10	60				200*	4.5	50*	84B	
	〃 524	〃	〃	〃	−25		−100	350	175	−0.1	−10				−10	10	50				250*	4.5	50*	49C	
★	〃 525	東芝	RF.Conv.Mix Osc	Ge.EMe	−20		−5	75	85	−10	−12				−6	1	20	PG = 21dB (f = 70MHz)			250*	1	25	48C	
★	〃 526	ソニー	PA	Si.E	−50	−40	−1A	500	150	−5	−50	70	−2	−100	−6	1	50	h_{fe} = 5dB (f = 50MHz)				18	$C_c r_{bb'}$ 100ps	84C	
★	〃 527	〃	〃	〃	−50	−40	−2A	5W (T_c=25°C)	150	−5	−50	50	−2	−200	−6	1	50	h_{fe} = 5dB (f = 50MHz)				18	$C_c r_{bb'}$ 100ps	97C	
★	〃 528	〃	〃	〃	−50	−40	−2A	5W (T_c=25°C)	150	−5	−50	70	−2	−100	−6	1	50	h_{fe} = 5dB (f = 50MHz)				18	$C_c r_{bb'}$ 100ps	97C	
★	〃 529	〃	RF.PA	Si.EMe	−50	−40	−1A	5W (T_c=25°C)	150	−5	−50	80	−2	−100	−10	50		h_{fe} = 5dB (f = 50MHz)				18	$C_c r_{bb'}$ 100ps	181	
	〃 530	日立	SW	Si.E	−50	−35	−100	200	175	−1	−20	35~200	−1	−10	−10	20		t_{on} = 90ns, t_{off} = 160ns t_{stg} < 300ns			200*	5		49C	
★	〃 531																								
★	〃 532	三洋	RF.PA	Si.TP	−50	−50	−200	500	150	−10	−40	80	−6		−6	10					90*	7	$C_c r_{bb'}$ 45ps	84B	2SC875 2SC876 とコンプリ
	〃 533																								
	〃 534																								
★	〃 535	三洋			−75		−700	500	150			60	−6	−50							80*			84B	2SC873 2SC874 とコンプリ
★	〃 536	〃			−50		−700	500	150			60	−6	−50							80*			84B	〃
★	〃 537	日立	SW	Si.EP	−60	−50	−700	750	200	−1	−30	50~160	−4	−50	−10	20		t_{on} = 42ns, t_{off} = 280ns t_{stg} = 230ns			150*	<35	30	84B	2SC708とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SA537A	日立	RF.SW	Si.EP	−100	−80	−700	750	200	−1	−30	50~160	−4	−50	−10	20		t_{on}=42ns, t_{off}=290ns t_{stg}=240ns			150*	15	30	84B	2SC708A とコンプリ
★	〃 538	東芝	〃	Ge.A	−25		−50	120	75	−50	−25				−6	1	70				8	10	100	12A	
★	〃 539	日電	PA	Si.E	−60	−45	−200	250	125	−0.1	−45	80	−1.0	−50	−10	10	80				200*	8.5	20	138	2SC815 とコンプリ
★	〃 540																								
★	〃 541																								
★	〃 542	日電	RF. AF	Si.E	−30	−25	−50	150	150	−0.05	−25	160	−10	−0.5	−5	1	180	5000	2	28	100*	5	20*	23	
★	〃 543	〃	RF. LN	〃	−30	−25	−50	150	150	−0.05	−25	160	−10	−0.5	−5	1	180	5000	2	28	100*	5	20*	23	
	〃 544	〃	RF. SW	〃	−60	−45	−200	750	175	−0.1	−45	130	−10	−10	−10	10	100				250*	4	30	84B	2SC32 とコンプリ
★	〃 545	〃	PA	〃	−70	−60	−200	400	125	−0.1	−45	80	−1	−50	−10	10	110				200*	8.5	20	44	2SC853 とコンプリ
★	〃 546	松下	PA	Si.EP	−70	−60	−1A	750	175	−3	−30	80	−3	−100	−10	50					80*	50	20	84B	2SC696 とコンプリ
★	〃 546A	〃	〃	〃	−90	−80	−1A	750	175	−3	−30	80	−3	−100	−10	50					80*	50	20	84B	2SC696A とコンプリ
★	〃 547	〃	〃	〃	−70	−60	−1A	10 W (Tc=25°C)	175	−3	−30	80	−3	−100	−10	50					80*	50	20	97B	2SC697 とコンプリ
★	〃 547A	〃	〃	〃	−90	−80	−1A	10 W (Tc=25°C)	175	−3	−30	80	−3	−100	−10	50					80*	50	20	97B	2SC697A とコンプリ
★	〃 548	日立	RF.SW	〃	−50	−35	−100	200	175	−1	−20	100	−12	−1	−10	20	t_{on}=90ns, t_{off}=160ns t_{stg}=150ns				400*	4	C_c $r_{bb'}$ 30ps	8C	
★	〃 549	〃	RF	Si.T	−70	−70	−100	200	175	−1	−20	80.	−1	−10	−10	10					200*	2.5	80*	182C	○
★	〃 550	松下	RF.AF	〃	−25	−25	−100	300	175	−1	−10	250	−5	−2	−5	2	150	3000	3	50	120*	5	100	49C	2SC538 とコンプリ
★	〃 550A	〃	〃	〃	−45	−45	−100	300	175	−1	−10	250	−5	−2	−5	2	150	3000	3	50	120*	5	100	49C	2SC538A とコンプリ
★	〃 551	三洋	〃	Si.EP	−70	−70	−400	600	150	−10	−70	40~200	−4	−200	−4	10					80*				
	〃 552	日電	RF.SW	Si.E	−60	−45	−200	750	175	−0.1	−45	100	−10	−10	−10	10	100	t_{on}<100ns, t_{off}<300ns t_{stg}<270ns			150*	8	10*	84B	
	〃 553	富士通	RF	Si.EP	−40		−300	250	175	−0.1	−10				−10	10	60				200*	4.5	50*	49C	
	〃 554	〃	〃	〃	−25		−300	250	175	−1	−10				−10	10	60				200*	4.5	50*	49C	
	〃 555	〃	〃	〃	−50		−200	200	125	−1	−10	80	−1	−10	−6	2					200*	55	40*	138	
	〃 556	〃	〃	〃	−20		−200	200	125	−1	−10				−10	10	60				200*	5	50*	138	
★	〃 557	〃	〃	〃	−80		−600	800	175	−1	−30	120	−2	−200							100*	18	20*	84B	
	〃 558	〃	SW	〃	−40	−35R	−200	350	175	−0.1	−10	50	−1	−10				t_r=10ns, t_f=25ns t_s=90ns			200*	4.5	50*	49C	
	〃 559	〃	〃	〃	−20	−20R	−200	350	175	−0.5	−10	50	−1	−10				t_r=10ns, t_f=25ns t_s=90ns			200*	4.5	50*	49C	○
★	〃 560	東芝 富士通	RF	Si.TP	−80	−60	−800	800	175	−0.5	−30	30~120	−2	−150	−10	50	70				150*	11	15	84B	
★	〃 561	東芝	〃	Si. E	−50	−50	−150	300	125	−0.1	−18	70~400	−1	−20	−6	1					70*	13	10	33	2SC734 とコンプリ
	〃 562	〃	AF.	〃	−35	−30	−500	500	150	−0.1	−35	70~240	−1	−100	−6	20					200	13		138	2SC1959 とコンプリ
★	〃 563																								

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SA564	松下	RF. AF	Si. EP	−25	−25	−100	400	150	−1	−10	250	−10	−2	−10	1					80*	3.5	100	138	2SC828とコンプリ
	〃 564A	〃	〃	〃	−45	−45	−100	400	150	−1	−10	250	−10	−2	−10	1					80*	3.5	100	138	2SC828Aとコンプリ
★	〃 565	日立	RF	〃	−50	−50	−500	300	175	−0.5	−20	80	−3	−10	−6	1					60*	5	30*	12A	2SC984とコンプリ
★	〃 566	〃	PA	〃	−100	−100	−700	10 W (T_c=25°C)	175	−10	−30	35〜200	−4	−50	−4	30					100*	25		153	2SC680とコンプリ
★	〃 567	〃	RF	〃	−30	−30	−100	200	175	−0.5	−15	400	−6	−0.1	−6	1	300	10k	4	25	70*	5	25*	12A	
★	〃 568	三菱	PA	〃	−35	−30	−250	200	125	−1	−25	100	−2	−150	−6	10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	
★	〃 569	〃	PA	〃	−50	−45	−250	200	125	−1	−25	100	−2	−150	−6	10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	
★	〃 570	〃	〃	〃	−65	−60	−250	200	125	−1	−25	80	−2	−150	−6	10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	
	〃 571	日電	SW. RF	Si. E	−60	−45	−1A	800	175	−0.1	−45	80	−10	−50	−10	50	t_{on}<40ns, t_{off}<160ns t_{stg}<130ns				300*	16	30	123	2SC97Aとコンプリ
★	〃 572	新日無	RF.AF.LN	Si. EP	−30	−25	−50	200	125	−0.05	−20	180	−6	−1	−6	1					120*	4.5		29	
★	〃 573	〃	RF. AF	〃	−30	−25	−100	300	125	−0.1	−20	100	−6	−1	−6	1	120	5000	1.5	20	150*	4	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138	2SC950とコンプリ
★	〃 574	〃	RF	〃	−60	−50	−100	300	125	−0.1	−20	130	−1	−50	−6	1	120	5000	1.5	20	150*	4	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138	2SC951とコンプリ
★	〃 575	〃	〃	〃	−90	−85	−100	300	125	−0.1	−20	100	−1	−50	−6	1	120	5000	1.5	20	150*	4	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138	2SC952とコンプリ
★	〃 576	〃	RF. PA	〃	−30	−30	−200	600	125	−0.5	−20	80	−1	−100	−10	5					200*	5	$C_c r_{bb'}$ 50ps	31	2SC953とコンプリ
★	〃 577	〃	〃	〃	−60	−60	−400	600	125	−0.5	−20	100	−1	−100	−10	5					200*	5	$C_c r_{bb'}$ 50ps	31	2SC954とコンプリ
	〃 578	日電	RF. AF. LN	Si. E	−50	−40	−30	300	150	−0.05	−30	370	−3	−1	−6	1		9.5k	2.5	30	180*	8.5	20*	49C	2SC1010とコンプリ
	〃 579	〃	RF. AF	〃	−50	−40	−30	300	150	−0.05	−30	370	−3	−1	−6	1		9.5k	2.5	30	180*	8.5	20*	49C	2SC1006とコンプリ
	〃 580	富士通	RF. AF. PA	Si. EP	−60	−40	−600	800	175	−1	−30	120	−2	−200	−6	1		4000	0.5	15	100*	18	20*	84B	
	〃 581	〃	〃	〃	−100	−70	−600	800	175	−1	−30	120	−2	−200	−6	1		4000	0.5	15	100*	18	20*	84B	
★	〃 582																								
★	〃 583																								
★	〃 584																								
★	〃 585																								
★	〃 586																								
★	〃 587	東芝																							
★	〃 588	〃																							
★	〃 589	〃																							
★	〃 590	〃																							
★	〃 591	〃																							
★	〃 592	〃																							

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SA593	東芝																								
	〃 594	東芝、日電	RF.SW	Si. E	−60	−45	−200	750	175	−0.1	−45	40~240	−1	−10	−10	10					200*	3.5	<120*	84B	2SC594とコンプリ
★	〃 595	東芝																								
★	〃 596	〃																								
★	〃 597	〃	RF.PA	Si.EP	−50	−40	−1A	6 W (T_c=25°C)	175	−1	−30	50	−3	−150	−10	100					400*	10	10*	84B	
★	〃 598	〃																								
★	〃 599	〃																								
★	〃 600	〃																								
★	〃 601	〃																								
★	〃 602	〃																								
	〃 603	日電	RF.SW	Si.E	−60	−40	−200	300	150	−0.5	−40	140	−1	−10	−10	10					250*	7.5	70	49C	2SC943とコンプリ
★	〃 604	〃	〃	〃	−120	−100	−30	300	150	−0.5	−100	80	−3	−1	−10	10					170*	3	20	49C	
★	〃 605	〃	RF. SW	〃	−180	−160	−50	300	150	−1	−100	100	−6	−15	−10	10					100*	4	40	49C	
★	〃 606	〃	PA	〃	−100	−80	−700	700	150	−3	−80	100	−5	−200	−10	100					>50*	<50	45*	84B	2SC959とコンプリ
★	〃 607	〃	〃	〃	−100	−80	−700	1 W	150	−3	−80	80	−5	−200	−10	100					>50*	<50	45*	97B	2SC960とコンプリ
	〃 608	三洋	RF. AF. SW	Si.EP	−40	−30	−100	100	125	−1	−25	150	−6	−1	−6	10					180*	7	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138	
★	〃 609	〃	RF. AF	〃	−30	−15	−100	100	125	−1	−25	85	−6	−1	−6	1					80*	7	$C_c r_{bb'}$ 100ps	27	
★	〃 610	新日無	〃	〃	−30	−25	−100	150	12	−1	−20	100	−6	−1	−6			5000	1.5	20	170*	3.3	$C_c r_{bb'}$ 50ps	27	
★	〃 611	〃	〃	〃	−60	−50	−100	150	125	−1	−20	100	−6	−1	−6	1		5000	1.5	20	170*	3.3	$C_c r_{bb'}$ 50ps	27	
★	〃 612	〃	RF. SW	〃	−90	−85	−50	200	175	−1	−70	100	−6	−1	−10	2					150*	4	$C_c r_{bb'}$ 50ps	243	
★	〃 613	日電	PA	Si.E	−60	−40	−1A	15W (T_c=25°C)	150	−1mA	−40	80	−5	−500	−10	200					30*	60	140*	134	2SD150とコンプリ
★	〃 614	〃	〃	〃	−80	−60	−1A	15W (T_c=25°C)	150	−1mA	−60	80	−5	−500	−10	200					30*	60	140*	134	
★	〃 615	〃	〃	〃	−70	−50	−3A	25W (T_c=25°C)	150	−1mA	−60	80	−5	−1A										134	2SD255とコンプリ
★	〃 616	〃	〃	Si.EMe	−80	−60	−3A	25W (T_c=25°C)	150	−1mA	−60	70	−5	−1A	−10	200					15*	100	60*	134	2SD155とコンプリ
★	〃 617	日立	RF	Si.T	−150	−150R	−50	200	175	−1	−100	80	−3	−15	−10	10					60*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 40ps	182C	
★	〃 618	〃	〃	〃	−180	−180R	−50	200	175	−1	−150	80	−3	−15	−10	10					60*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 40ps	182C	
★	〃 619	芝電																								
★	〃 620	新日無	RF. AF. LN	Si.EP	−30	−25	−50	200	175	−50nA	−20	250	−6	−1	−6	0.3	190	21k	3.4	6.2	120*	3	$C_c r_{bb'}$ 55ps	243	
★	〃 621	〃	RF. AF	〃	−60	−60	−200	400	175	−0.5	−20	80	−1	−50	−10	5					200*	6	$C_c r_{bb'}$ 50ps	84B	
★	〃 622	〃	SW	Si.EP ダーリントン	−30	−25	−300	150	125	−0.1	−20	40,000	−6	−100			t_{on}<600ns, t_{off}<1.2μs t_{stg}<600ns							27	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SA623	三菱	SW. PA	Si. EP	−35	−20	−1.5A	7 W (Tc=25℃)	150	−1	−25	100	−4	−500				t_{on}<0.2μs, t_{off}<0.8μs t_s<0.6μs						132	2SC1013 とコンプリ
★	〃 624	〃	〃	〃	−50	−40	−1.5A	7 W (Tc=25℃)	150	−1	−25	100	−4	−500				〃						132	2SC1014 とコンプリ
	〃 625	富士通	RF	〃	−100	−70	−500	700	175	−1	−30	120	−2	−200	−10	10					100*	18	20	84B	
★	〃 626	日電	PA	Si. EMe	−80	−70	−6A	60W (Tc=25℃)	150	−100	−70	60	−5	−2A	−10	200					10*	300	60*	102	2SD180 とコンプリ
★	〃 627	〃	〃	〃	−100	−80	−7A	60W (Tc=25℃)	150	−100	−80	60	−5	−2A	−10	200					10*	300	60*	102	2SD188 とコンプリ
★	〃 628	三菱	RF. AF. SW	Si. EP	−30	−25	−100	200	125	−0.1	−25	200	−6	−1	−6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	○
★	〃 629	〃	RF. AF. LN	〃	−30	−25	−30	150	125	−0.1	−25	200	−6	−1	−6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 60ps	138B	
★	〃 630	日立																							
★	〃 631	〃																							
★	〃 632	〃																							
★	〃 633	日電	PA	Si. E	−30	−20	−2A	10W (Tc=25℃)	150	−10	−30	80	−5	−1A	−5	150					60*	60	10*	167	
★	〃 634	〃	〃	〃	−40	−30	−3A	10W (Tc=25℃)	150	−1	−30	100	−5	−1A	−5	100					55*	75		167	2SC1096 とコンプリ
★	〃 635	〃	PA. SW	〃	−60	−40	−1A	10W (Tc=25℃)	150	−10	−40	80	−5	−500	−5	150					50*	60	10*	167	
★	〃 636	〃	〃	〃	−70	−45	−3A	10W (Tc=25℃)	150	−1	−45	100	−5	−500	−5	100					45*	60		167	2SC1098 とコンプリ ○
★	〃 637	松下	RF. AF	Si. TP	−150	−150R	−50	300	175	−1	−100	150	−3	−15	−10	3	67	540	0.4	7.7	150*	4	$C_c r_{bb'}$ 150ps	49C	
	〃 638	日電	〃	Si. E	−150	−150R	−50	250	125	−1	−100	100	−6	−15	−10	10					130*	4.5		138	2SC1278 とコンプリ
	〃 639	〃	〃	〃	−180	−180R	−50	250	125	−1	−100	100	−6	−15	−10	10					130*	4.5		138	2SC1279 とコンプリ
★	〃 640	〃	RF. AF. LN	〃	−50	−50	−50	250	125	−0.05	−50	450	−3	−0.5	−6	1	450	11k	15	50	100*	6.5	20*	138	2SC1222 とコンプリ
★	〃 641	〃	RF. AF	〃	−50	−50	−50	250	125	−0.05	−50	450	−3	−0.5	−6	1	450	11k	15	50	100*	6.5	20*	138	2SC923 とコンプリ
★	〃 642	〃	PA	〃	−30	−15	−300	250	125	−0.1	−15	120	−1	−50	−3	50					200*	15	12	138	2SD227 とコンプリ
★	〃 643	〃	〃	〃	−40	−20	−500	500	125	−0.2	−25	120	−1	−100	−6	50					180*	24	10	44	2SD261 とコンプリ
★	〃 644	〃																							
★	〃 645	三菱	PA. SW	Si. EP	−70	−60	−800	7 W (Tc=25℃)	150	−10	−25	100	−4	−300				t_{on}<200ns, t_{off}<800ns t_{stg}<600ns						132	2SC1155 とコンプリ
★	〃 646	〃	〃	〃	−90	−80	−800	7 W (Tc=25℃)	150	−10	−25	100	−4	−300				〃						132	2SC1156 とコンプリ
★	〃 647	〃	〃	〃	−110	−100	−800	7 W (Tc=25℃)	150	−10	−25	100	−4	−300				〃						132	2SC1157 とコンプリ
★	〃 648	日電	PA	Si. EMe	−120	−80	−7A	60W (Tc=25℃)	150	−2mA	−80	50	−5	−3A	−10	200					10*	200	30*	102	2SD217 とコンプリ
★	〃 649	〃	〃	〃	−150	−100	−7A	80W (Tc=25℃)	150	−2mA	−80	50	−5	−3A	−10	200					10*	200	30*	102	2SD218 とコンプリ
★	〃 650	〃	〃	〃	−150	−100	−10A	100W (Tc=25℃)	150	−1mA	−80	70	−5	−2A	−10	200					10*	500	20*	102	
★	〃 651	〃	〃	〃	−150	−120	−10A	100W (Tc=25℃)	150	−1mA	−100	70	−5	−2A	−10	200					10*	500	20*	102	
★	〃 652	〃	〃	〃	−150	−100	−1A	15W (Tc=25℃)	150	−1mA	−60	80	−5	−200	−10	200					15*	100	30*	134	2SC1160 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SA653	日電	PA	Si.EMe	−150	−120	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	80	−5	−200	−10	200					15 *	100	30 *	134	2SC1161 とコンプリ	○
★	〃 654	〃																								
★	〃 655	〃																								
★	〃 656	東芝	PA	Si.TMe	−130	−110	−7A	50W (Tc=25°C)	150	100	13	30~300	−5	−1A	−10	1A					5 *	150		102	2SC519 とコンプリ	○
★	〃 657	〃	〃	〃	−100	−80	−7A	50W (Tc=25°C)	150	100	100	30~300	−5	−1A	−10	1A					5 *	150		102	2SC520 とコンプリ	○
★	〃 658	〃	〃	〃	−70	−50	−7A	50W (Tc=25°C)	150	100	70	30~300	−5	−1A	−10	1A					5 *	150		102	2SC521 とコンプリ	○
	〃 659	三洋	RF	Si.P	−50	−50	−200	400	125	−10	−40	100	−6	−50	−6	10					90 *	7	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138	2SC1175 とコンプリ	
★	〃 660																									
★	〃 661	東芝	RF.AF.PA	Si.E	−70	−50	−200	600	150	−0.1	−20	40~400	−2	−50	−10	10					100 *	9	10	131	2SC1166 とコンプリ	
★	〃 662	〃																								
★	〃 663	〃	RF.AF.PA	Si.EP	−100	−80	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−50	30~200	−5	−1A	−5	1A					6 *	600	15	102	2SC793 とコンプリ	
★	〃 664	三洋																								
★	〃 665																									
★	〃 666	松下	RF.AF.LN	Si.EP	−25	−25	−50	150	125	−1	−10	250	−5	−2	−5	−2	200	5000	0.7	10	130 *	2.8	$C_c r_{bb'}$ 160ps	138		○
★	〃 667																									
★	〃 668	三菱	RF.SW	Si.EP	−100	−100	−100	150	125	−0.1	−25	100	−6	1	−6	1	t_{on}<120ns, t_{off}<290ns t_{stg}<100ns				100 *	3.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B		
★	〃 669	〃	SW	〃	−160	−150	−100	150	125	−0.1	−25	70	−6	1										138B		
★	〃 670	日立	PA.SW	Si.T	−50	−50	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−20	35~200	−4	−1A	−4	500					32 *	200		267	2SC1060 とコンプリ	
★	〃 671	〃	〃	〃	−50	−50	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−20	35~200	−4	−1A	−4	500					32 *	200		268	2SC1061 とコンプリ	
★	〃 672	〃	RF.LN	Si.EP	−50	−50	−200	200	125	−0.5	−18	110	−12	−2	−12	2					80 *	16	12 *	138		
	〃 673	〃	RF.AF	Si.E	−35	−35	−500	400	150	−0.5	−20	60~320	−3	−10										138	2SC1213 とコンプリ	○
★	〃 674	〃																								
	〃 675	日電	SW	Si.E	−80	−80	−100	250	125	−1	−60	120	−3	−20	−6	10					170 *	4.5		138		
★	〃 676	〃																								
★	〃 677	ソニー	RF.SW	Si.E	−25	−25	−200	250	100	−0.5	−25	250	−3	−1	−6	2		h_{fe}=3dB (f=100MHz)			140 *	6	$C_c r_{bb'}$ 60ps	38	2SC633A とコンプリ	
★	〃 678	〃	〃	〃	−50	−50	−200	320	120	−0.5	−25	250	−3	−1	−6	2		h_{fe}=3dB (f=100MHz)			140 *	6	$C_c r_{bb'}$ 60ps	38	2SC634A とコンプリ	
★	〃 679	東芝	PA	Si.EMe	−120	−120	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−50	40~140	−5	−2A	−5	2A					6 *	900	20	102	2SC1079 とコンプリ	
★	〃 680	〃	〃	〃	−80	−100	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−50	40~140	−5	−2A	−5	2A					6 *	900	20	102	2SC1080 とコンプリ	
★	〃 681	〃	RF.PA	Si.E	−100	−100	−1A	800	150	−1	−30	120	−2	−150	−2	150					50 *	40	10	342		
★	〃 682	〃	〃	〃	−80	−80	−750	800	150	−0.1	−30	70~240	−2	−150	−2	150					100 *	15	15	342	2SC1382 とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SA683	松下	PA	Si. EP	−30	−25	−1A	1 W	150	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	20	3.5*	294	2SC1383とコンプリ
	〃 684	〃	〃	〃	−60	−50	−1A	1 W	150	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	20	3.5*	294	2SC1384とコンプリ
★	〃 685	〃	AF	Si. TP	−150	−150R	−50	300	125	−1	−100	150	−3	−15	−10	3	67	540	0.4	77	100*	5	35	138	
★	〃 686																								
★	〃 687																								
★	〃 688																								
★	〃 689																								
★	〃 690																								
★	〃 691																								
★	〃 692																								
★	〃 693																								
★	〃 694																								
	〃 695	三菱	RF. PA	Si. EP	−25	−20	−700	500	125	−1	−25	100	−1	−500	−6	10					150*	20	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	2SC1209とコンプリ
	〃 696	〃	〃	〃	−45	−40	−300	500	125	−1	−25	100	−2	−150	−6	10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	2SC1210とコンプリ
	〃 697	〃	〃	〃	−65	−60	−300	500	125	−1	−25	100	−2	−150	−6	10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	2SC1211とコンプリ
★	〃 698	〃	PA. SW	〃	−130	−120	−800	7 W (T_c=25°C)	150	−10	−25	100	−4	−300			t_{on}<200ns, t_{off}<800ns t_{stg}<600ns							132	2SC1224とコンプリ
	〃 699	松下	PA	〃	−40	−32	−2A	10W (T_c=25°C)	150	−1	−20	120	−5	−1A	−5	500					150*	70	3.3*	161	2SC1226とコンプリ ○
★	〃 700	日立	〃	Si. E	−35	−35	−1.5A	8 W (T_c=25°C)	150	−10	−35	100	−2	−200	−4	500					11*	200	6*	268	
	〃 701	三洋	RF. LN	Si. EP	−30	−30	−50	200	125	−1	−25	200	−6	−1	−6	1		2200	0.5	7	80*	12	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138	
	〃 702	〃	〃	〃	−50	−50	−50	200	125	−1	−45	200	−6	−1	−6	1		2200	0.5	7	80*	12	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138	
★	〃 703	三菱	SW. PA	〃	−25	−20	−1.5A	7 W (T_c=25°C)	150	−1	−16	100	−4	−500				t_{on}<0.2μs, t_{off}<0.8μs t_{stg}<0.6μs						132	2SC1243とコンプリ
★	〃 704	ソニー	RF. AF. LN SW	Si. EMe	−25	−25	−200	250	100	−0.5	−25	250	−3	−1	−6	1		6600	0.76	16.2	h_{fe}=3dB (100MHz)	6	$C_c r_{bb'}$ 60ps	38	2SC631Aとコンプリ
★	〃 705	〃	〃	Si. E	−50	−50	−200	320	120	−0.5	−25	250	−3	−1	−6	1		h_{fe}=3dB (f=100MHz)			140*	6	$C_c r_{bb'}$ 60ps	38	2SC632Aとコンプリ
★	〃 706	〃	RF	Si. DB	−60	−60	−1A	950	120	−1	−50	150	−2	−100	−10	10					120*	10	$C_c r_{bb'}$ 150ps	174	
★	〃 707	日電	RF. PA	Si. E	−40	−20	−500	750	135	−0.2	−25	120	−1	−100	−3	50					180*	24	10	45	2SD336とコンプリ
	〃 708	〃	RF.AF.SW	〃	−80	−60	−700	800	150	−0.1	−60	150	−2	−50	−10	50					100*	25	25*	84B	2SC1008とコンプリ ○
★	〃 709	〃	〃	〃	−60	−40	−200	300	150	−0.1	−40	160	−1	−10	−10	10					280*	7.5	70*	304	
	〃 710	〃	RF. SW	〃	−50	−40	−100	300	150	−0.1	−30	120	−1	−10	−10	10	t_{on}<80ns, t_{off}<180ns t_{stg}<140ns				600*	2.5	34*	49C	
	〃 711	〃	〃	〃	−50	−40	−100	300	150	−0.1	−30	120	−1	−10	−10	10	t_{on}<70ns, t_{off}<170ns t_{stg}<130ns				1000*	2.5	34*	49C	
	〃 712	〃	〃	〃	−150	−150	−500	750	175	−0.1	−100	110	−10	−50	−10	50					350*	5.5	11*	84B	2SC1217とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SA713	日電	RF	Si.E ダーリントン	−15	−15	−300	250	125	−0.1	−10	20,000	−5	−100	−10	10					180*	6	200*	138	2SC1280とコンプリ	○
★	〃 714	三洋	PA	Si.EMe	−150	−100	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−30	60	−5	−1A	−5	1A					8*	500	20	102	2SC1051とコンプリ	
	〃 715	日立	RF.PA	Si.E	−35	−35	−2.5A	10W (Tc=25°C)	150	−20	−35	60~320	−2	−500	−2	200					160*	35		160	2SC1162とコンプリ	
★	〃 716	三洋																								
	〃 717	日電	RF.SW	Si.E	−60	−40	−1A	800	175	−0.1	−40	80	−10	−50	−10	50					280*	18	10*	123	2SC1072とコンプリ	
	〃 718	〃	〃	〃	−60	−40	−200	300	150	−0.1	−40	140	−1	−10	−10	10					250*	7	30*	49C		
	〃 719	松下	PA	Si.EP	−30	−25	−500	625	150	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6	3.5*	138	2SC1317とコンプリ	
	〃 720	〃	〃	〃	−60	−50	−500	625	150	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6	3.5*	138	2SC1318とコンプリ	
★	〃 721	〃	RF.LN	〃	−35	−35	−50	400	150	−0.1	−10	540	−5	−2	−5	2		3500	3	60	250*	5	100	138	2SC1327とコンプリ	
★	〃 722	〃	〃	〃	−55	−55	−50	400	150	−0.1	−10	540	−5	−2	−5	2		3500	3	60	250*	5	100	138	2SC1328とコンプリ	
★	〃 723	日電	PA	Si.E	−40	−20	−500	250	125	−0.2	−25	120	−1	−100	−3	50					180*	24	10	138	2SD327とコンプリ	
	〃 724	〃	RF	〃	−35	−30	−50	250	125	−0.1	−25	150	−10	−0.5	−1	10					300*	3.5	20*	138		
★	〃 725	三菱	RF.AF.LN	Si.EP	−35	−35	−100	200	125	−0.1	−25	500	−6	−1	−6	1		15k	1.2	28	100*	3	$C_c r_{bb'}$ 140 ps	138B		
★	〃 726	〃	〃	〃	−50	−50	−100	200	125	−0.1	−50	500	−6	−1	−6	1		15k	1.2	28	100*	3	$C_c r_{bb'}$ 60 ps	138B		
★	〃 727	〃																								
★	〃 728	〃	RF.AF	Si.EP	−30	−25	−100	100	125	−0.1	−25	200	−6	−10	−6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 60 ps	175		○
★	〃 729	〃																								
★	〃 730	松下	PA	Si.EP	−30	−25	−500	600	125	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6	3.5*	171	2SC1346とコンプリ	
★	〃 731	〃	〃	〃	−60	−50	−500	600	125	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6	3.5*	171	2SC1347とコンプリ	
	〃 732	富士通	RF	〃	−40	−30	−300	650	175	−0.1	−10	60	−10	−10	−10	10					200*	4.5	50*	84B		
	〃 733	日電	RF.AF	Si.E	−60	−50	−100	250	125	−0.1	−60	200	−6	−1	−6	1	205	5500	7.5	28	180*	4.5	12	138	2SC945とコンプリ	
★	〃 734	ソニー																								
★	〃 735	〃																								
★	〃 736	〃																								
★	〃 737	〃																								
	〃 738	日立	PA	Si.E	−25	−25	−2.5A	8W (Tc=25°C)	150	−20	−25	60~320	−2	−500	−2	200					160*	35		160	2SC1368とコンプリ	
	〃 739	東芝	SW	Si.TMe	−400	−400	−3A	50W (Tc=25°C)	150	−100	−300	20~300	−5	−500	−50							100		102		
★	〃 740	〃	RF.PA	〃	−150	−150	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−20	−100	75	−10	−500	−10	500					8*	100	25	268	2SC1448とコンプリ	○
	〃 741	日立	SW	Si.E	−20	−20	−100	360	175	−0.2	−16	30~120	−0.5	−30	−10	10		t_{on}<70ns, t_{off}<120ns			350*			49C		
	〃 742	〃	〃	〃	−60	−60	−500	700	175	−0.5	−20	80~200	−1.6	−100	−20	50		t_{on}<40ns, t_{off}<100ns			>200*	<8		123		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SA743	日立	RF.PA	Si.E	−50	−50	−1A	8 W (Tc=25°C)	150	−1mA	−50	120	−4	−50	−4	30					120*	30		160	2SC1212とコンプリ	○
★	〃 744	サンケン	PA	Si.TMe	−80	−80	−8A	70W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	60	−4	−3A	−12	500					15*	220	10*	102	2SC1402とコンプリ	
★	〃 745	〃	〃	〃	−100	−100	−8A	70W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	60	−4	−3A	−12	500					15*	220	10*	102	2SC1403とコンプリ	○
★	〃 746	〃	〃	〃	−80	−80	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	60	−4	−3A	−12	500					15*	255	10*	102	2SC1115とコンプリ	
★	〃 747	〃	〃	〃	−120	−120	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−120	60	−4	−3A	−12	500					15*	255	10*	102	2SC1116とコンプリ	○
	〃 748	松下	RF.PA	Si.EP	−70	−50	−2A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−40	130	−5	−1A	−5	500					120*	50	3*	268	2SC1398とコンプリ	
★	〃 749	〃	SW	〃	−100	−100	−50	250	125	−0.1	−50	80	−1	−20	−10	10		t_r<350ns, t_f<150ns t_{stg}<200ns			>40*	3.5		138		○
★	〃 750	日電	RF.AF.LN	Si.E	−50	−50	−50	250	125	−0.05	−50	450	−3	−0.5	−6	1	450	11k	15	50	100*	8	20*	138		
★	〃 751	松下	PA	Si.EP	−30	−25	−1A	1 W	135	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	20	3.5*	173	2SC1406とコンプリ	
★	〃 752	〃	〃	〃	−60	−50	−1A	1 W	135	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	20	3.5*	173	2SC1407とコンプリ	
★	〃 753	日立	〃	Si.T	−140	−110	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−30	30~200	−5	−1A	−5	1 A					20*	220		102	2SC1343とコンプリ	
★	〃 754	〃	〃	〃	−50		−2A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−20	35~200	−4	−1A										267	2SC1418とコンプリ	
★	〃 755	〃	〃	〃	−50	−50	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−20	35~200	−4	−1A	−4	500					50*			268	2SC1419とコンプリ	
★	〃 756	〃	〃	〃	−100	−80	−6A	50W (Tc=25°C)	150	−1mA	−30	80	−5	−1A	−5	1 A					20*	240		102	2SC1030とコンプリ	
★	〃 757	〃	〃	〃	−120	−90	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−30	25~200	−5	−1A	−5	1 A					24*	250		102	2SC897とコンプリ	
★	〃 758	〃	〃	〃	−130	−110	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−1mA	−30	25~200	−5	−1A	−5	1 A					20*	250	10*	102	2SC898とコンプリ	
	〃 759	日電	RF.PA	Si.E	−60	−45	−200	150	125	−0.1	−45	180	−1	−50	−10	10					200*	8.5	20	176		
	〃 760	〃	〃	〃	−50	−45	−30	150	125	−0.1	−40	350	−3	−0.5	−3	1					100*	8	20*	176		
★	〃 761	ソニー	〃	Si.EP	−110	−110	−2A	6.3W (Tc=25°C)	120	−10	−50	100	−2	−400	−2	200					80*	55	$C_c r_{bb'}$ 98ps	181		
★	〃 762	〃	〃	〃	−110	−110	−2A	1.5W	150	−10	−50	100	−2	−400	−2	200					80*	50	$C_c r_{bb'}$ 95ps	99		
★	〃 763	新日無	RF.AF.LN	〃	−30	−25	−50	200	125	−50nA	−20	250	−6	−1	−6	0.3	190	21k	3.4	6.2	120*	3	$C_c r_{bb'}$ 55ps	138	2SC949とコンプリ	
★	〃 764	サンケン	PA	Si.EMe	−60	−60	−6A	40W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	80	−4	−1A	−10	500					10*	90	8*	99	2SC1444とコンプリ	
★	〃 765	〃	〃	〃	−80	−80	−6A	40W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	80	−4	−1A	−10	500					10*	90	8*	99	2SC1445とコンプリ	
★	〃 766	松下	〃	Si.Me	−150	−150R	−400	20W (Tc=80°C)	150	−30	−60	60	−5	−100	−10	100					15*	100	25	153	2SC1450とコンプリ	
★	〃 767	東芝	RF	Si.EP	−55	−50	−100	200	150	−0.1	−30	120	−1	−10	−10	1					150*	5	20	195		
	〃 768	サンケン	PA	Si.EMe	−60	−60	−4 A	30W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	60	−4	−1A	−10	200					10*	60	12*	298	2SC1826とコンプリ	
	〃 769	〃	〃	〃	−80	−80	−4 A	30W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	60	−4	−1A	−10	200					10*	60	12*	298	2SC1827とコンプリ	
	〃 770	〃	〃	〃	−60	−60	−6 A	40W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	80	−4	−1A	−12	500		t_r=0.9μs, t_f=0.1μs t_{stg}=1μs			10*	120	30	298	2SC1985とコンプリ	
	〃 771	〃	〃	〃	−80	−80	−6 A	40W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	80	−4	−1A	−12	500		t_r=0.9μs, t_f=0.1μs t_{stg}=1μs			10*	120	30	298	2SC1986とコンプリ	
★	〃 772	ソニー	RF.PA	Si.EP	−16	−16	−2A	750	120	−0.2	−16	350	−2	−100	−2	−10					80*	50	$C_c r_{bb'}$ 600ps	294	2SC1474とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SA773	ソニー	RF. PA	Si. EP	−60	−50	−1A	750	120	−0.2	−25	250	−2	−100	−2	10					65*	25		294	2SC1475とコンプリ	
★	〃 774	松下	RF. LN	Si. EP	−35	−35	−50	150	175	−0.1	−10	540	−5	−2	−5	2		3500	3	60	120*	5	100	243		○
★	〃 775	日立	PA	Si. T	−120	−120	−2A	12.5W (T_c=25°C)	150	−10	−30	90	−4	−50	−4	30					30*	35	25	268	2SC1410とコンプリ	○
★	〃 776	東芝	RF. LN	Si. EP	−55	−50	−50	200	150	−0.1	−30	300	−6	−2	−6	1	285	7300	1	21	180*	3	35	195		○
	〃 777	松下	PA	〃	−80	−80	−500	1W	150	−0.1	−20	160	−10	150	−10	50					120*	11		294	2SC1509とコンプリ	
	〃 778	日立	SW	Si. T	−150	−150R	−50	200	125	−1	−100	100	−3	−15	−3	15					50*	<10		138	2SC1516とコンプリ	○
	〃 779	〃	RF.PA.SW	Si. E	−35	−35	−1.5A	10W (T_c=25°C)	150	−20	−30	60~200	−2	−500	−2	200	t_{on}=130ns, t_{off}=550ns t_{stg}=450ns				110*	50		234		
	〃 780	〃	PA. SW	〃	−50	−50	−1A	10W (T_c=25°C)	150	−1	−30	120	−4	−50	−4	50					120*	8		234	2SC1517とコンプリ	○
	〃 781	〃	SW. RF	〃	−20	−15	−200	200	150	−0.2	−16	20~200	−0.5	−30	−1	30	t_{on}<70ns, t_{off}<120ns				550*	25		138		
★	〃 782	ローム	RF. Conv. Mix Osc. PA. AF	〃	−80	−80R	−30	150	150	−1	−50	150	−6	−1	−6	1		7.1k	0.4	6.7	200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160ps	235		
★	〃 783	〃	〃	〃	−50	−40	−30	150	125	−1	−30	150	−6	−1	−6	1		7.1k	0.4	6.7	200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160ps	235		
★	〃 784	〃	〃	〃	−25	−20	−30	150	125	−1	−15	130	−6	−1	−6	1		7.1k	0.4	6.7	200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160ps	235		
	〃 785	〃	〃	〃	−80	−80R	−50	250	125	−1	−50	150	−3	−10	−5	1		6.7k	0.8	10	180*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138		
★	〃 786	〃	〃	〃	−50	−40	−50	150	125	−1	−30	150	−3	−10	−5	1		6.7k	0.8	10	180*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	235		
★	〃 787	〃	〃	〃	−20	−20	−50	150	125	−1	−15	150	−3	−10	−6	1		6.7k	0.8	10	180*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	235		
★	〃 788	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA. AF. LN	〃	−50	−40	−30	150	125	−1	−30	150	−3	−10	−6	1	NF=2dB (f=1kHz)	7.1k	0.4	6.7	200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160ps	235		
★	〃 789	〃	〃	〃	−25	−20	−30	150	125	−1	−15	150	−3	−10	−6	1	NF=2dB (f=1kHz)	7.1k	0.4	6.7	200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160ps	235		
	〃 790	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	−40	−32S	−300	300	125	−1	−24	10,000	−5	−100	−5	10					200*	3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138		
★	〃 791	〃	〃	〃	−25	−20S	−300	300	125	−1	−15	10,000	−5	−100	−5	10					200*	3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	235		
★	〃 792	富士通																								
	〃 793	〃	RF	Si. EP	−80	−60	−600	800	175	−1	−30	120	−2	−200	−10	10					100*	18	20*	84B		
	〃 794	松下	PA	〃	−100	−100	−500	1.2W	150	−1	−100	160	−10	−150	−10	50					120*	20		222	2SC1567とコンプリ	○
★	〃 795	〃	〃	〃	−150	−150	−250	10W (T_c=25°C)	150	−30	−60	120	−10	−100	−10	50					120*	<15	15	236	2SC1565とコンプリ	○
★	〃 796	新日無	SW	〃	−30	−25	−300	300	125	−1	−20	40,000	−6	−100			t_{on}<600ns, t_{off}<1.2μs t_{stg}<600ns							138	2SC1432とコンプリ	
★	〃 797	三菱	RF	〃	−90	−90	−50	150	125	−0.1	−50	500	−6	−1	−6	1	500	14k	0.8	19	100*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	8A	2SC1572とコンプリ	
	〃 798	〃	Diff. LN	〃	−50	−50	−100	200 unit	125	−0.1	−35	250~1200	−6	1	−6	1	ΔV_{BE}<10mV h_{FE}小/h_{FE}大=0.8~1.0				100*	3.0		274A	2素子複合	
	〃 799	富士通	SW	〃	−60	−60	−1.5A	1W	200	−0.5	−50	54	−1	−500			t_{on}<45ns, t_{off}<110ns t_{stg}<80ns							84C		
	〃 800	日電	RF	Si. E	−20	−12	−30	250	200	−0.1	−15	60	−10	−10	−10	10	$\|S_{21e}\|^2$> 5dB (10V, 10mA, 1GHz)				2500*	0.9		50C		
★	〃 801	〃	〃	〃	−20	−12	−50	300	200	−0.1	−10	90	−10	−15	−5	15	$\|S_{21e}\|^2$=10dB (10V, 20mA, 1GHz)				4000*	1.2		130		
	〃 802	ローム	SW	Si. TP	−130	−130R	−30	150	125	−1	−80	56~270	−3	−5	−5	2					50*	8		138		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CB}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CE}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SA803	ローム	RF. AF	Si.EP	−130	−130R	−30	150	125	−1	−80	150	−6	−1	−5	10					200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160ps	235		
★	〃 804	〃	〃	〃	−130	−130R	−50	150	125	−1	−80	120	−3	−10	−5	10					180*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	235		
	〃 805	〃	SW	Si.TP	−180	−180R	−30	150	125	−1	−120	56~270	−3	−5	−5	2					50*	8		138		
	〃 806	〃	〃	〃	−210	−210R	−30	150	125	−1	−150	56~270	−3	−5	−5	2					50*	8		138		
★	〃 807	サンケン	PA	Si.EMe	−60	−60	−6A	50W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	60	−4	−3A	−12	500					10*	90	8*	102	2SC1618とコンプリ	
★	〃 808	〃	〃	〃	−80	−80	−6A	50W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	60	−4	−3A	−12	500					10*	90	8*	102	2SC1619とコンプリ	○
★	〃 809	富士通	RF	Si.EP	−150	−120	−50	700	175	−1	−140	150	−5	−10	−5	10	t_{on}<1μs t_{off}<10μs t_{stg}<9.5μs				100*	3	70*	248		
★	〃 810	〃	〃	〃	−150	−150	−50	700	175	−1	−140	150	−5	−10	−5	10	t_{on}<1μs t_{off}<10μs t_{stg}<9.5μs				100*	3	70*	248		
★	〃 811	日電	RF. AF	Si.E	−50	−45	−30	150	125	−0.05	−40	400	−3	−0.5	−3	1		9200	2.7	33	100*	8	20*	176		○
	〃 812	〃	〃	〃	−60	−50	−100	200	150	−0.1	−60	200	−6	−1	−6	10		5500	7.5	28	180*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 35ps	176	2SC1623とコンプリ	
★	〃 813	〃	RF. PA	〃	−60	−45	−200	150	125	−0.1	−45	80	−1	−50	−10	10					200*	8.5	20	176		
	〃 814	東芝	PA	Si.Eb Me	−120	−120	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−50	70~240	−5	−150	−5	150					30*	30		268	2SC1624とコンプリ	
	〃 815	〃	〃	〃	−100	−100	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−50	70~240	−5	−150	−5	150					30*	30		268	2SC1625とコンプリ	
	〃 816	〃	〃	Si. E	−80	−80	−750	15W (Tc=25°C)	150	−0.5	−30	70~240	−2	−150	−2	150					100*	20		268	2SC1626とコンプリ	
	〃 817	〃	〃	〃	−80	−80	−300	600	150	−0.1	−50	70~240	−2	−50	−10	10					100*	14		138	2SC1627とコンプリ	○
★	〃 818	〃	〃	Si. T	−180	−150	−50	1 W	150	−1	−100	70~240	−5	−10	−10	10					120*	<5		249	2SC1628とコンプリ	
★	〃 819	ローム	RF	Si.EP	−40	−32	−300	300	125	−1	−20	180	−3	−100	−5	20					240*	7	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138		
	〃 820	〃	SW	Si.TP	−180	−180R	−30	250	125	−1	−120	56~270	−3	−5	−5	2					50*	8		235		
	〃 821	〃	〃	〃	−210	−210R	−30	250	125	−1	−150	56~270	−3	−5	−5	2					50*	8		235		
★	〃 822	〃	RF. AF	Si.EP	−80	−80R	−30	250	125	−1	−80	120	−6	−1	−5	10					200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160ps	138		
★	〃 823	〃	〃	〃	−50	−40	−30	250	125	−1	−30	180	−6	−1	−5	10					200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160ps	138		
★	〃 824	〃	〃	〃	−25	−20	−30	250	125	−1	−15	220	−6	−1	−5	10					200*	3	$C_c r_{bb'}$ 160ps	138		
	〃 825	〃	AF. RF Osc.SW	〃	−80	−80R	−50	250	125	−1	−50	82~390	−3	−10	−5	10					180*	6.5		235		
★	〃 826	〃	〃	〃	−50	−40	−50	250	125	−1	−30	82~390	−3	−10	−5	10					180*	6.5		138		
★	〃 827	〃	RF. AF	〃	−25	−20	−50	250	125	−1	−15	150	−3	−10	−5	10					180*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138		
★	〃 828	〃	RF. LN	〃	−50	−40	−30	250	125	−1	−30	180	−3	−10	−5	10	NF= 2 dB (−5V,−0.1mA, f=1kHz)				180*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138		
★	〃 829	〃	〃	〃	−25	−20	−30	250	125	−1	−15	220	−3	−10	−5	10	NF= 2 dB (−5V,−0.1mA, f=1kHz)				180*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138		
	〃 830	〃	AF	〃	−40	−32S	−300	300	125	−1	−24	>1000	−5	−100	−5	10					200*	3		235	ダーリントン	
★	〃 831	〃	〃	〃	−25	−20S	−300	300	125	−1	−15	>1000	−5	−100	−5	10					200*	3		138	ダーリントン	
	〃 832	〃	SW	Si.TP	−130	−130R	−30	250	125	−1	−80	56~270	−3	−5	−5	2					50*	8		235		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SA833	ローム	RF.AF	Si.EP	−130	−130R	−30	250	125	−1	−80	150	−6	−1	−5	10					200*	3	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138		
★	〃 834	〃	〃	〃	−130	−130R	−50	250	125	−1	−80	120	−3	−10	−5	10					180*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138		
★	〃 835	ソニー	〃	Si. E	−140	−140	−500	950	120	−0.2	−100	150	−2	−100	−10	20					45*	30		174	2SC1663とコンプリ	
	〃 836	日立	LN	〃	−55	−55	−100	200	150	−0.1	−18	160~500	−12	−2	−12	2	NF=0.5dB (f=1kHz, V_{CE}=−6V, I_C=−0.1mA)				200*	2		138		
★	〃 837	松下	RF. PA	Si.EMe	−90	−90	−4A	50W (T_C=75°C)	150	−1mA	−50	100	−4	−1A	−10	500					10*	200	10	102	2SC1667とコンプリ	
	〃 838	〃	RF	Si. EP	−30	−20	−30	400	150	−0.1	−10	100	−10	−1	−10	1					300*	1.2	22	138	2SC1359とコンプリ	
	〃 839	東芝	PA	Si.T	−150	−150	−1.5A	25W (T_C=25°C)	150	−20	−100	40~240	−10	−500	−10	500					6*	50		268	2SC1669とコンプリ	
★	〃 840	ソニー	AF. RF	Si. E	−140	−140	−500	750	120	−0.2	−100	150	−2	−100	−10	20					45*			294	2SC1670とコンプリ	
★	〃 841	東芝	LN	Si. EP	−60	−60	−50	200	125	−0.1	−35	450	−6	−2	−6		450	11.2k	1	24	140*	NF=3dB (f=10Hz)		33		
★	〃 842	〃	〃	〃	−40	−40	−50	200	125	−0.1	−35	450	−6	−2	−6			11.2k	1		140*	NF=1.5dB (f=10Hz)		33		
★	〃 843	松下	RF. PA	Si.EMe	−200	−150	−50	20W (T_C=25°C)	150	−50	−200	120	−10	−400	−10	200					35*	80	25	268	2SC1683とコンプリ	
	〃 844	日立	RF.AF	Si. E	−55	−55	−100	300	150	−0.1	−18	160~500	−12	−2	−12	2					200*	2		138		
	〃 845	〃	AF.SW	〃	−150	−150R	−50	200	175	−1	−100	80	−3	−15	−10	10					>40*	<10		49C		○
★	〃 846	〃																								
	〃 847	三菱	AF. LN. RF	Si. EP	−90	−90	−50	200	125	−0.1	−50	250~1200	−6	−1	−6	1	V_{NO}<170mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				150*	2.5		138B	2SC1708とコンプリ	○
★	〃 848	富士通	AF	〃	−150		−50	1 W	175	−1	−140	150	−5	−10	−5	10					100*	3		90	2SC1719とコンプリ	
★	〃 849	〃	〃	〃	−150		−50	1 W	175	−1	−140	150	−5	−10	−5	10					100*	3		90	2SC1720とコンプリ	
★	〃 850	三菱	AF. Drive	〃	−100	−100	−500	800	135	−1	−50	55~300	−10	−10	−10	10					130*	11		242		
★	〃 851	〃	RF. AF	〃	−50	−50	−100	500	125	−0.1	−25	400	−5	−2	−5	10					150*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138F		
★	〃 852	〃	〃	〃	−35	−35	−100	500	125	−0.1	−25	500	−5	−2	−5	10					150*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138F		
★	〃 853	〃	RF.AF.LN	〃	−35	−35	−100	500	125	−0.1	−25	600	−5	−2	−5	10	NF=0.5dB (−6V, −0.1mA, 1kHz)				150*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138F		
	〃 854	ローム	AF.SW	〃	−40	−32	−500	400	125	−1	−20	82~390	−3	−100	−5	20					200*	7.5		138	2SC1741とコンプリ	
★	〃 855	東芝	RF, LN	〃	−60	−60	−50	150	150	−0.1	−35	450	−6	−1	−6	1	450	11.2k	1	24	140*	4.5	40	49C		
★	〃 856	〃	〃	〃	−50	−50	−50	150	150	−0.1	−35	450	−6	−1	−6	1	NF=1.5dB (f=100Hz, V_{CE}=−6V, I_E=1mA)				140*	4.5	40	49C		○
	〃 857	富士通	AF	Si. EP	−150	−120	−50	500	150	−1	−140	150	−5	−10	−5	10					100*	3		138		
	〃 858	〃	〃	〃	−150	−150	−50	500	150	−1	−140	150	−5	−10	−5	10					100*	3		138		
	〃 859	モトローラ	RF	Si. E	−300	−300	−500	625	150	−0.25	−200	125	−10	−10	−20	10					120*	3	$C_c r_{bb'}$ 300ps	138D	MPSA92	
	〃 860	〃	〃	〃	−200	−200	−500	625	150	−0.25	−160	125	10	−10	−20	10					120*	3	$C_c r_{bb'}$ 300ps	138D	MPSA93	
★	〃 861	ソニー	RF. AF	〃	−20	−16	−2A	950	120	−0.2	−16	140~451	−2	−100	−2	10					80*	50		174B	2SC1761とコンプリ	
★	〃 862																									

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SA863																									
★	〃 864																									
★	〃 865																									
★	〃 866	新日無	RF	Si. EP	−30	−25	−100	300	125	−0.1	−20	250	−6	−1	−10	2					150*	4	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138D	
★	〃 867	〃	〃	〃	−60	−50	−100	300	125	−0.1	−20	250	−6	−1	−10	2					150*	4	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138D	
★	〃 868	〃	〃	〃	−90	−90	−100	300	125	−0.1	−20	250	−6	−1	−10	2					150*	4	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138D	
★	〃 869	〃	〃	〃	−30	−25	−400	500	125	−0.5	−20	200	−1	−100	−10	5					150*	8	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138D	
★	〃 870	〃	〃	〃	−60	−60	−400	500	125	−0.5	−20	200	−1	−100	−10	5					150*	8		138D	
★	〃 871	〃	RF. AF. LN	〃	−30	−25	−50	200	125	−0.05	−20	250	−6	−1	−6	0.3		50k	4	10	120*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 55ps	138D	
	〃 872	日立	LN	Si. E	−90	−90	−50	300	150	−0.5	−75	250~800	−12	−2	−12	2	NF<1.5dB (f=1kHz, V_{CE}=−6V, I_C=−50μA)				120*	1.8		138	2SC1775 とコンプリ ○
	〃 873	富士通	RF	Si. EP	−60	−40	−200	300	150	−0.5	−40	140	−1	−10	−10	10					220*	5	70*	275	
	〃 874	ローム	AF.SW	〃	−40	−32	−500	300	125	−1	−20	82~390	−3	−100	−5	20					200*	7.5		235	2SC1652 とコンプリ
★	〃 875	日電																								
	〃 876	日立	RF. SW	Si.E	−70	−50	−500	350	175	−0.5	−50	80~240	−3	−10	−3	10	t_{on}=35ns, t_{off}=300ns t_{stg}=250ns				110*	10		49C	2SC1781 とコンプリ
	〃 877	サンケン	PA	Si.EMe	−80	−80	−10A	100W (T_c=25°C)	150	−100	−80	60	−4	−3A	−12	500					15*	255	10*	102	
★	〃 878	〃	〃	〃	−120	−120	−10A	100W (T_c=25°C)	150	−100	−120	60	−4	−3A	−12	500					15*	255	10*	102	
	〃 879	松下	RF. AF	Si. EP	−250	−200	−70	1W	150	−10	−250	100	−10	−5	−10	3		300	0.4	2.7	80*	5	$C_c r_{bb'}$ 60ps	294	2SC1573 とコンプリ
★	〃 880	〃	RF. LN	Si. EP	−35	−35	−50	150	125	−0.1	−10	540	−5	−2	−5	2		3.5k	3	60	120*	5	100	276	2SC1787 とコンプリ
	〃 881	ローム	RF. AF	〃	−40	−32	−1A	600	125	−0.5	−20	180	−3	−100	−5	50					150*	20	$C_c r_{bb'}$ 80ps	235	2SC2673 とコンプリ
★	〃 882	松下	PA	Si. EMe	−130	−130	−7A	100W (T_c=25°C)	150	−500	−70	150	−5	−7A	−10	500					7*	800	10	102	2SC1818 とコンプリ
★	〃 883	日電	RF. SW	Si. E	−60	−40	−200	300	150	−0.1	−40	160	−1	−10	−10	10	t_{on}=100ns, t_{off}=270ns t_{stg}=200ns				280*	7.5		138	
★	〃 884	ソニー	RF	〃	−65	−65	−200	270	120	−0.5	−50	250	−3	−1	−6	2					140*	6	$C_c r_{bb'}$ 60ps	277	Pc=250mW /unit
	〃 885	松下	PA	Si. EP	−45	−35	−1A	1.2W	150	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	20	3.5k*	222	2SC1846 とコンプリ
	〃 886	〃	〃	〃	−50	−40	−1.5A	1.2W	150	−1	−20	120	−5	−1A	−5	500					150*	70	3.3k*	222	2SC1847 とコンプリ
	〃 887	〃	〃	〃	−70	−50	−2A	1.2W	150	−1	−40	130	−5	−1A	−5	500					150*	50	3k*	161	2SC1848 とコンプリ
★	〃 888	〃	RF. AF	〃	−25	−25	−50	350	135	−1	−10	250	−5	−2	−5	2	150	3k	3	50	100*	2.7	100	138D	2SC1849 とコンプリ
★	〃 889	〃	〃	〃	−45	−45	−50	350	135	−1	−10	250	−5	−2	−5	2	150	3k	3	50	100*	2.7	100	138D	2SC1850 とコンプリ
★	〃 890	〃	PA	〃	−30	−25	−500	625	135	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6	3.5k*	138D	2SC1851 とコンプリ
★	〃 891	〃	〃	〃	−60	−50	−500	625	135	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6	3.5k*	138D	2SC1852 とコンプリ
★	〃 892	サンケン	SW	〃	−40	−40	−6A	40W (T_c=25°C)	150	−100	−40	>300	−4	−5A	−12	100	t_r=0.7μs, t_f=0.7μs t_{stg}=1.2μs				15*			298	ダーリントン

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FF}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SA893	日立	RF.AF	Si. E	−90	−90	−50	300	150	−0.5	−75	250~800	−12	−2	−12	2	NF=2dB (1kHz, 6V, 50μA)				120*	1.8		138	2SC1890とコンプリ ○
★	〃 894	新日無	RF	Si. EP	−30	−25	−1A	600	125	−0.5	−20	200	−1	−100	−10	50					150*	25	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138	
★	〃 895	〃	〃	〃	−30	−25	−30	200	125	−0.5	−20	100	−6	−1	−10	2					500*	1	$C_c r_{bb'}$ 8 p/s	138	
★	〃 896	ソニー	〃	Si. E	−200	−150	−100	750	120	−0.2	−100	150	−5	−3	−10	10					70*	3	$C_c r_{bb'}$ 50ps	294	2SC1811とコンプリ
★	〃 897	〃	〃	〃	−60	−50	−2A	950	120	−0.2	−25	250	−2	−100	−2	10					55*	25	$C_c r_{bb'}$ 350ps	174B	
	〃 898	富士通	AF.RF	Si.EP	−150	−120	−50	1 W	175	−1	−140	150	−5	−50	−5	10					100*	3	70*	328	
	〃 899	〃	〃	〃	−150	−150	−50	1 W	175	−1	−140	150	−5	−50	−5	10					100*	3	70*	328	
	〃 900	松下	PA	〃	−20	−18	−1A	1.2W	150	−1	−10	200	−2	−500	−6	50					200*	40		222	2SC1568とコンプリ
★	〃 901	三菱	AF.RF	〃	−40	−40	−100	200	125	−0.1	−35	250~1200	−6	−1	−6	1					100*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138B	
★	〃 902	〃	RF.AF.LN	〃	−50	−50	−100	200	125	−0.1	−35	600	−6	−1	−6	1	NF=0.5dB (−6V, −0.1mA, 1kHz)				150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138	
★	〃 903	〃	RF. AF	〃	−50	−50	−100	200	125	−0.1	−35	600	−6	−1	−6	1					150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138	
	〃 904	〃	AF.RF	〃	−90	−90	−50	200	125	−0.1	−50	250~1200	−6	−1	−6	1					150*	2.5		138B	○
★	〃 905	〃	〃	〃	−120	−120	−50	800	135	−1	−100	150~800	−10	−10	−10	10					200*	3		242	2SC1915とコンプリ
★	〃 906	〃	LN	Si.E	−40	−40	−100	200	125	−0.1	−35	250~1200	−6	−1	−6	1	V_{NO}<200mV (−10V, −1mA, R_G=100kΩ, G_V=80dB)				100*	3.5	40	138B	
★	〃 907	サンケン	PA	Si.EMe	−100	−100	−15A	150W (T_c=25°C)	150	−1 mA	−100	80	−4	−5 A	−12	500					10*	270	10*	102	2SC1584とコンプリ
★	〃 908	〃	〃	〃	−150	−150	−15A	150W (T_c=25°C)	150	−1 mA	−150	80	−4	−5 A	−12	500					10*	270	10*	102	2SC1585とコンプリ
★	〃 909	〃	〃	〃	−200	−200	−15A	150W (T_c=25°C)	150	−1 mA	−200	80	−4	−5 A	−12	500					10	270	10*	102	2SC1586とコンプリ
★	〃 910	富士通																							
★	〃 911	ソニー	RF	Si. E	−850	−550	−100	470	120	−1.5	−100	50	−5	−10	−10	10	t_s=650ns, t_{stg}=500ns t_r=500ns, t_f=850ns				9*	8	$C_c r_{bb'}$ 70ps	181	2SC1762とコンプリ
★	〃 912	松下	PA	Si.EP	−150	−150	−50	750	135	−1	−100	200	−5	−10	−10	10					200*	3		294	2SC1885とコンプリ
★	〃 913	〃	RF	〃	−150	−150	−1 A	15W (T_c=25°C)	150	−10	−150	150	−10	−150	−10	50					120*	<15		268	2SC1913とコンプリ ○
	〃 914	〃	〃	〃	−150	−150	−50	1 W	150	−1	−100	150	−5	−10	−10	10					200*	<5		222	2SC1953とコンプリ
	〃 915	日電	AF	Si. E	−120	−120	−50	1 W	150	−0.1	−120	200	−10	−10	−10	10					80*	2.5		278	2SC1940とコンプリ
	〃 916	〃	〃	〃	−160	−160	−50	1 W	150	−0.1	−160	200		−10	−10	10					80*	2.5		278	2SC1941とコンプリ
★	〃 917	ソニー	RF	〃	−120	−120	−100	750	120	−0.2	−100	150	−5	−3	−10	10					70*	3	$C_c r_{bb'}$ 50ps	294	2SC1951とコンプリ
	〃 918	富士通	〃	Si.EP	−40	−25	−300	300	150	−0.1	−10	60	−10	−10	−10	10					200*	4.5	50*	275	
★	〃 919	ソニー	SW	Si. T	−850	−550	−100	950	120	−10	−650	50	−5	−10	−10	10	t_{on}<1μs, t_f<1.5μs t_{stg}<5.5μs				9*	8	$C_c r_{bb'}$ 70ps	174B	
★	〃 920	〃	RF	Si. E	−200	−200	−500	950	120	−0.2	−200	120	−2	−100	−10	100					40*	25	$C_c r_{bb'}$ 46ps	174	
	〃 921	松下	〃	Si. EP	−120	−120	−20	400	150	−0.1	−50	600	−5	−2	−30	1					200*	3	70	138	2SC1980とコンプリ
★	〃 922	ソニー	〃	Si. E	−80	−80	−1A	625	150	−0.1	−50	150	−2	−100	−10	10					120*	10	$C_c r_{bb'}$ 150ps	181	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SA923	ソニー	RF	Si. E	−200	−150	−200	625	150	−0.2	−100	150	−5	−3			h_{fe} = 17dB (−10V, 10mA, 10MHz)					3	$C_c r_{bb'}$ 50ps	181	2SC805A とコンプリ
★	〃 924	日立	RF. AF	〃	−30	−30	−100	500	150	−0.5	−24	100~320	−12	−2										138D	
★	〃 925	ソニー	RF	Si. EPa	−30	−30	−30	250	120	−0.2	−30	200	−3	−1	−6	2					450*	3	$C_c r_{bb'}$ 65ps	138	2SC1908 とコンプリ
★	〃 926	日電																							
	〃 927	富士通	RF. AF	Si. EP	−60	−40	−250	500	150	−0.5	−40	140	−1	−10	−10	10					290*	5.5	70*	138	
★	〃 928	ソニー	RF	Si. E	−20	−20	−1A	250	120	−0.2	−20	150	−2	−100	$\lvert h_{fe} \rvert$ = 13dB (−10V, 10mA, 10MHz)							18	10*	138	
	〃 929	三洋	AF. LN	Si. EP	−55	−50	−50	200	125	−0.1	−30	160~960	−6	−1	−6	1	V_{NO} < 35mV (30V, 1mA, R_G = 56kΩ, A_v = 77dB)				80*	5		138	2SC1570 とコンプリ
	〃 930	〃	〃	〃	−40	−35	−50	200	125	−0.1	−30	160~960	−6	−1	−6	1	V_{NO} < 35mV (30V, 1mA, R_G = 56kΩ, A_v = 77dB)				80*	5		138	2SC1571 とコンプリ
★	〃 931	富士通	RF	〃	−150		−50	450	175	−1	−140	150	−5	−10							100*	5	70*	182C	
★	〃 932	〃	〃	〃	−150		−50	450	175	−1	−140	150	−5	−10							100*	5	70*	182C	
	〃 933	ローム	AF. RF Osc. SW	〃	−50	−40	−100	300	125	−0.5	−30	82~390	−6	−1	−12	2					140*	4		138	2SC1740 とコンプリ
	〃 934	〃	AF	〃	−40	−32	−700	750	125	−0.5	−20	82~390	−3	−100	−5	50					150*	20		294	2SC2060 とコンプリ
	〃 935	〃	〃	〃	−80	−80	−700	750	125	−0.5	−50	82~390	−3	−100	−10	50					100*	14		294	2SC2061 とコンプリ
	〃 936	〃	〃	〃	−40	−32S	−300	300	125	−1	−30	>10000	−5	−10	−5	10					200*	4		138	ダーリントン
	〃 937	〃	AF. RF Osc. SW	〃	−50	−40	−100	300	125	−0.5	−30	82~390	−6	−1	−12	2					140*	4		235	2SC2021 とコンプリ
★	〃 938	ソニー	RF. AF. SW	Si.PaMe	−50	−50	−500	500	120	−0.2	−50	150	−2	−100	−10	10	t_r < 100ns, t_f < 150ns t_{stg} < 400ns				h_{fe} = 10 (f = 10MHz)	11	$C_c r_{bb'}$ 120ps	138	
	〃 939	富士通	RF. AF	Si. EP	−250	−220	−50	1 W	150	−1	−200	150	−5	−10	−5	10					100*	3	70*	328	
	〃 940	東芝	PA	Si.T	−150	−150	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−120	75	−10	−500	−10	500					4*	55		268	2SC2073 とコンプリ
★	〃 941	〃	LN	Si. E	−120	−120	−50	300	125	−0.1	−120	200~700	−6	−2	−6	1	NF = 1 dB (−6V, 0.1mA, 10Hz)				150*	2.8		138	2SC2088 とコンプリ
★	〃 942	〃	〃	〃	−90	−90	−50	300	125	−0.1	−90	200~700	−6	−2	−6	1	NF < 6 dB (−6V, 0.1mA, 100Hz)				150*	2.8		138	2SC2089 とコンプリ
★	〃 943	日電																							
★	〃 944	〃																							
★	〃 945	〃																							
★	〃 946	富士通																							
★	〃 947	東芝																							
★	〃 948	〃																							
	〃 949	〃	AF. SW	Si. T	−150	−150	−50	800	150	−0.1	−150	70~240	−5	−10	−30	10					120*	4		241	2SC2229 とコンプリ
	〃 950	〃	PA	Si. EP	−30	−30	−800	600	150	−0.1	−35	100~320	−1	−100	−5	10					120*	19		138	2SC2120 とコンプリ
★	〃 951	ソニー	〃	Si.EPa	−140	−140	−500	950	120	−0.2	−100	150	−2	−100	−10	20					45*	30		174B	
	〃 952	日電	AF. PA	Si. E	−30	−25	−700	600	150	−0.1	−30	200	−1	−100	−6	10					160*	17		138	2SC2001 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SA953	日電	AF.PA	Si.E	−60	−60	−300	600	150	−0.1	−60	200	−1	−50	−6	10					100*	13		138	2SC2002とコンプリ
	〃 954	〃	〃	〃	−80	−80	−300	600	150	−0.1	−80	200	−1	−50	−6	10					100*	13		138	2SC2003とコンプリ
	〃 955	〃																							
	〃 956	〃	RF.AF.SW	Si.E	−60	−40	−100	150	125	−0.1	−40	160	−1	−10	−10	10	t_{on}=100ns, t_{off}=270ns t_{stg}=200ns				280*	7.5		176	
	〃 957	サンケン	PA	Si.EMe	−150	−150	−2A	30W (T_c=25°C)	150	−100	−150	100	−10	−0.7A	−12	200					20*	35	35	298	2SC2167とコンプリ
	〃 958	〃	〃	〃	−200	−200	−2A	30W (T_c=25°C)	150	−100	−200	100	−10	−0.7A	−12	200					20*	35	35	298	2SC2168とコンプリ
	〃 959	日電	SW	Si.E	−100	−100	−10A	100W (T_c=25°C)	150	−100	−100	30~200	−5	−5A			t_{on}<1μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							102	
★	〃 960	〃																							
★	〃 961	〃																							
★	〃 962	東芝	PA	Si.E	−60	−50	−1.5A	1W	150	−1	−50	70~240	−2	−150	−10	100					100*	30		249	2SC2194とコンプリ
	〃 963	松下	〃	Si.EP	−50	−40	−1.5A	10W (T_c=25°C)	150	−1	−20	120	−5	−1A	−5	500					150*	70		236	2SC2209とコンプリ
★	〃 964	日電	〃	Si.E	−200	−200	−200	10W (T_c=25°C)	150	−1	−180	180	−10	−10	−10	10					100*	3	16*	167C	○
	〃 965	東芝	AF	〃	−120	−120	−800	900	150	−0.1	−120	80~240	−5	−100	−5	100					120*	<40	40	241	2SC2235とコンプリ
	〃 966	〃	PA	〃	−30	−30	−1.5A	900	150	−0.1	−30	100~320	−2	−500	−2	500					120*	<30		241	2SC2236とコンプリ
★	〃 967	〃																							
	〃 968	〃	PA	Si.E	−160	−160	−1.5A	25W (T_c=25°C)	150	−1	−160	70~240	−5	−100	−10	100					100*	30		268	2SC2238とコンプリ ○
★	〃 969	〃	〃	〃	−160	−160	−1.5A	25W (T_c=25°C)	150	−1	−160	70~240	−5	−100	−10	100					100*	30		99	2SC2239とコンプリ
	〃 970	〃	AF.LN	〃	−120	−120	−100	300	125	−0.1	−120	200~700	−6	−1	−6	1	NF<6dB (f=10Hz, 6V, 100μA)		NF<2dB (f=1kHz)		100*	4		138	2SC2240とコンプリ
★	〃 971	サンケン	PA	Si.EMe	−150	−150	−15A	150W (T_c=25°C)	150	−100	−150	60	−4	−5A	−12	500					10*	270	18*	102	
★	〃 972	松下	AF	Si.EP	−30	−25	−100	250	135	−1	−10	250	−10	−2	−10	2					150*	5.5		138	
★	〃 973	〃	RF	〃	−60	−55	−50	400	150	−0.1	−30	500	−5	−2	−10	1					70*	15	13	138	2SC2263とコンプリ
★	〃 974																								
★	〃 975																								
★	〃 976																								
★	〃 977	松下	PA	Si.EP	−180	−180	−50	1W	150	−1	−100	180	−5	−10	−10	10					80*	3.5	50	222	○
★	〃 978	三菱	AF.LN.RF	〃	−40	−40	−100	200	125	−0.1	−35	150~1200	−6	−1	−6	10	V_{NO}<300mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				125*	13	13	138B	
	〃 979	〃	LN.Diff	〃	−100	−100	−50	200/unit	125	−0.1	−70	250~800	−6	−1	−6	1	ΔV_{BE}<10mV h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0				150*	2.5		274A	2素子複合
★	〃 980	サンケン	PA	Si.TMe	−100	−100	−8A	80W (T_c=25°C)	150	−100	−100	>30	−4	−3A	−12	500					20*			102	2SC2260とコンプリ
★	〃 981	〃	〃	〃	−120	−120	−8A	80W (T_c=25°C)	150	−100	−120	>30	−4	−3A	−12	500					20*			102	2SC2261とコンプリ
★	〃 982	〃	〃	〃	−140	−140	−8A	80W (T_c=25°C)	150	−100	−140	>30	−4	−3A	−12	500					20*			102	2SC2262とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	旧名又は試作名	
2SA983	日電	RF	Si. E	−30	−25	−20	200	125	−0.1	−25	40~200	−10	−3	−10	3	G_{pe}>14dB, NF=4.5dB (12V, 3mA, 900MHz)				1000*	0.5		210A	フォワードAGC	
〃 984	三洋	AF	Si. EP	−60	−50	−500	500	150	−1	−40	60~320	−5	−50	−10	10					120*	9		138	2SC2274とコンプリ	
〃 985	日電	PA	Si. E	−120	−120	−1.5A	25W (T_c=25°C)	150	−1	−120	150	−5	−300	−5	200					180*	29		268	2SC2275とコンプリ	○
★ 〃 986	〃	〃	〃	−130	−130	−7A	80W (T_c=25°C)	150	−50	−120	150	−5	−1A	−5	1A					60*	250	10	295		
〃 987	〃	AF	〃	−40	−35	−100	500	125	−0.05	−40	400	−6	−1	−6	1					90*	<10		138		
〃 988	〃	〃	〃	−120	−120	−50	500	125	−0.05	−120	500	−6	−1	−6	1					100*	2		138		
〃 989	〃	〃	〃	−60	−50	−100	250	125	−1	−60	200	−6	−1	−6	10					180*	4.5	12	138		
〃 990	〃	LN	〃	−60	−50	−100	250	125	−0.1	−60	400	−6	−1	−6	1	NV=25mV (5V, 1mA, G_v=80dB, FLAT)				180*	4.5	13	138		
〃 991	〃	AF.LN	〃	−60	−60	−100	500	125	−0.05	−60	400	−6	−1	−6	1	V_{NO}<45mV (5V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				90*	5.5		138	2SC1844とコンプリ	
〃 992	〃	〃	〃	−120	−120	−50	500	125	−0.05	−120	500	−6	−1	−6	1	V_{NO}<40mV (5V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				100*	2		138	2SC1845とコンプリ	
★ 〃 993	日立	RF.AF	〃	−50	−50	−500	625	150	−0.1	−50	60~320	−3	−150	−3	10					120*	8		138D	2SC2277とコンプリ	
★ 〃 994	三菱	AF	Si. EP	−40	−40	−300	500	125	−0.1	−35	150~1200	−6	−1	−6	1					125*	13	$C_c r_{bb'}$ 25ps	138B		
〃 995	〃	定電流回路	〃	−100	−100	−50	200/unit	125	−0.1	−100	250~800	−6	−1	−6	1	I_{C2}/I_{C1}=0.8~1.25 ΔV_{BE}<10mV				100*	3		274C	2素子複合	
★ 〃 996																									
★ 〃 997	富士通	RF	Si. EP	−20	−20	−1A	500	150	−0.5	−15	200	−5	−10	−5	10					150*	10	15*	138		
★ 〃 998	〃	〃	〃	−50	−50	−1A	500	150	−0.5	−40	200	−5	−10	−5	10					150*	10	15*	138		
〃 999	三菱	AF	Si. E	−50	−50	−200	300	125	−0.1	−50	90~800	−6	−1	−6	10	NF<20dB (6V, 0.3mA, 100Hz)				200*	5.5		138	2SC2320とコンプリ	
★ 〃 1000	〃																								
★ 〃 1001	富士通	PA	Si. EP	−130	−130	−8A	80W (T_c=25°C)	150	−50	−130	100	−5	−500	−10	1A					40*	350		102	2SC2321とコンプリ	
★ 〃 1002	〃	〃	〃	−120	−120	−12A	120W (T_c=25°C)	150	−50	−120	100	−5	−500	−10	1A					40*	450		102	2SC2322とコンプリ	
★ 〃 1003	〃	〃	〃	−150	−150	−12A	120W (T_c=25°C)	150	−50	−150	100	−5	−500	−10	1A					40*	450		102	2SC2323とコンプリ	
★ 〃 1004	日立	RF.AF	Si. E	−40	−40	−100	310	150	−0.1	−18	160~800	−12	−2	−12	2					200*	1.8		138D		
〃 1005	日電	RF	〃	−40	−40	−30	250	125	−0.1	−40	90	−10	−1	−10	1	NF=3.5dB (−10V, −1mA, f=1MHz)				400*	1.1	$C_c r_{bb'}$ <20ps	138		
〃 1006	〃	PA	〃	−180	−180	−1.5A	25W (T_c=25°C)	150	−1	−150	120	−5	−150	−10	100					80*	45	10*	268	2SC2336とコンプリ	○
★ 〃 1007	〃	PA. SW	〃	−150	−130	−10A	100W (T_c=25°C)	150	−50	−150	150	−5	−1A	−5	200	t_{on}=0.2μs, t_{off}=1μs t_{stg}=0.7μs				50*	250		102	2SC2337とコンプリ	○
〃 1008	〃	SW	〃	−100	−100	−2A	15W (T_c=25°C)	150	−10	−100	40~200	−5	−1A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							268	2SC2331とコンプリ	
〃 1009	〃	〃	Si. T	−350	−350	−2A	15W (T_c=25°C)	150	−10	−350	80	−5	−100			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							268		○
〃 1010	〃	〃	Si. E	−100	−100	−7A	40W (T_c=25°C)	150	−10	−100	40~200	−5	−3A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							268	2SC2334とコンプリ	
★ 〃 1011	三洋	PA	Si. EP	−180	−160	−1.5A	25W (T_c=25°C)	150	−10	−120	60~200	−5	−300	−10	50					100*	30		268	2SC2344とコンプリ	
〃 1012	東芝	SW	Si. E	−60	−50	−5A	25W (T_c=25°C)	150	−1	−50	70~240	−1	−1A	−4	1A	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_{stg}=1μs				60*	170		268	2SC2562とコンプリ	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1013	東芝	RF.AF	Si.E	−160	−160	−1A	900	150	−1	−150	60~320	−5	−200	−5	100					>15*	<35	25	241	2SC2383とコンプリ
★ 〃 1014	〃	PA	〃	−160	−160	−1A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−150	60~320	−5	−200	−5	200					>15*	<35	25	249	2SC2384とコンプリ
〃 1015	〃	AF	〃	−50	−50	−150	400	125	−0.1	−50	70~400	−6	−2	−10	1	NF<10dB (f=1kHz, 6V, 0.1mA)				>80*	4	30	138	2SC1815とコンプリ
〃 1016	三洋	AF.LN	Si.EP	−120	−100	−50	400	125	−1	−80	160~960	−6	−1	−6	1	V_{NO}<35mV (30V, 1mA, R_G=56kΩ, A_r=77dB)				110*	2.2		138	2SC2362とコンプリ
〃 1017	〃	AF	〃	−120	−100	−50	500	125	−1	−80	100~560	−6	−1	−6	1					110*	2.2		138	2SC2363とコンプリ
〃 1018	松下	AF.RF	〃	−250	−200	−70	750	150	−1	−120	30~220	−10	−5	−10	10					>50*	<10		138	2SC1473とコンプリ
〃 1019	三洋	AF	〃	−150	−120	−50	900	150	−1	−80	100~560	−6	−1	−6	1					110*	2.2		294	2SC2375とコンプリ
〃 1020	東芝	PA.SW	Si.E	−50	−50	−2A	900	150	−1	−50	70~240	−2	−500	−2	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_{stg}=1μs				100*	40		241	2SC2655とコンプリ
★ 〃 1021	〃	RF.PA	〃	−150	−150	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−150	60~320	−5	−200	−5	200					>15*	<35		342	2SC2481とコンプリ
〃 1022	松下	RF	Si.EP	−30	−20	−30	200	125	−0.1	−10	50~220	−10	−1	−10	1	NF=2.8dB (5MHz, 10V, 1mA)				>150*	C_{rc} 1.2	Z_{rb} 22	176	2SC2295とコンプリ
〃 1023	日電	AF	Si.E	−70	−70	−100	250	125	−0.1	−70	200	−6	−1	−6	10	NF=6dB (6V, 0.3mA, 100Hz)				180*	4.5		138	2SC2378とコンプリ
〃 1024	日立	SW	Si.T	−400	−360	−100	400	150	I_{CEO} −1	−150	35~200	−20	−20	−10	10					15*	4		49C	2SC2267とコンプリ
〃 1025	〃	RF.AF	Si.E	−60	−60	−100	400	150	−0.1	−50	250~800	−12	−2	−12	2					90*	3.5	12	138	2SC2396とコンプリ
★ 〃 1026	三菱	RF	Si.EP	−50	−50	−200	250	125	−0.5	−50	250	−3	−1	−6	2					100*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 50ps	39	
★ 〃 1027	〃	RF.LN	〃	−50	−50	−200	250	125	−0.5	−50	300	−3	−1	−6	2	NF=0.7dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				100*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 50ps	39	
★ 〃 1028	ソニー	PA	Si.EPa	−100	−100	−10A	95W (Tc=25°C)	120	−10	−50	>50	−2	−100	−2	1A					60*	370		102	2SC2398とコンプリ
〃 1029	日立	AF	Si.E	−30	−30	−100	200	150	−0.5	−18	100~500	−12	−2	−12	2					280*	3.3		138	2SC458とコンプリ
〃 1030	〃	〃	〃	−55	−50	−100	200	150	−0.5	−18	100~320	−12	−2	−12	2					280*	3.3		138	2SC2308とコンプリ
〃 1031	〃	AF.LN	〃	−30	−30	−100	200	150	−0.5	−18	100~500	−12	−2	−12	2	NF<5dB (−6V, 0.1mA, 120Hz)				280*	3.3		138	2SC458LGとコンプリ
〃 1032	〃	〃	〃	−55	−50	−100	200	150	−0.5	−18	100~320	−12	−2	−12	2	NF<5dB (−6V, 0.1mA, 120Hz)				280*	3.3		138	2SC2310とコンプリ
★ 〃 1033	〃	AF	〃	−30	−30	−100	310	125	−0.5	−18	100~500	−12	−2	−12	2					280*	3.1		138D	2SC1766とコンプリ
〃 1034	松下	AF.LN	Si.EP	−35	−35	−50	200	125	−1	−10	180~1040	−5	−2			V_{NO}=110mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_r=80dB)							176	2SC2405とコンプリ
〃 1035	〃	〃	〃	−55	−55	−50	200	125	−1	−10	180~1040	−5	−2										176	2SC2406とコンプリ
〃 1036	ローム	AF.Osc.SW	〃	−40	−32	−500	200	125	−1	−20	82~390	−3	−100	−5	20					200*	7		335	2SC2411とコンプリ
〃 1037	〃	AF.RF Osc.SW	〃	−50	−40	−100	200	125	−0.5	−30	82~390	−6	−1	−12	2	NF=0.5dB (1kHz, 6V, 1mA)				140*	3.5		335	2SC2412とコンプリ
〃 1038	〃	AF.LN	〃	−120	−120	−50	300	125	−0.5	−100	180~820	−6	−2	−12	2	V_{NO}<150mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_r=80dB)				140*	3.2		138	2SC2389とコンプリ
〃 1039	〃	〃	〃	−80	−80	−50	300	125	−0.5	−75	180~820	−6	−2	−12	2	V_{NO}<150mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_r=80dB)				140*	3.2		138	2SC2390とコンプリ
〃 1040	富士通	SW	〃	−120	−120	−10A	100W (Tc=25°C)	175	−50	−120	100	−5	−1A	−10	1A	t_r=0.2μs, t_f=0.12μs t_{stg}=0.7μs				60*	350		102	2SC2430とコンプリ
〃 1041	〃	〃	〃	−120	−120	−15A	100W (Tc=25°C)	175	−50	−120	100	−5	−1.5A	−10	1A	t_r=0.2μs, t_f=0.12μs t_{stg}=0.7μs				60*	350		102	2SC2431とコンプリ
〃 1042	〃	〃	〃	−70	−70	−15A	100W (Tc=25°C)	175	−50	−70	100	−5	−1.5A	−10	1A	t_r=0.2μs, t_f=0.12μs t_{stg}=0.7μs				60*	350		102	2SC2432とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SA1043	富士通	SW	Si. EP	−120	−120	−30A	150W (Tc=25°C)	175	−50	−120	100	−5	−3A	−10	2A	t_r=0.2μs, t_f=0.08μs t_{stg}=0.24μs				60 *	600		103	2SC2433 とコンプリ	
	〃 1044	〃	〃	〃	−70	−70	−30A	150W (Tc=25°C)	175	−50	−70	100	−5	−3A	−10	2A	t_r=0.2μs, t_f=0.08μs t_{stg}=0.24μs				60 *	700		103	2SC2434 とコンプリ	
	〃 1045	〃	〃	〃	−100	−100	−10A	100W (Tc=25°C)	175	−50	−100	3000	−3	−2A										102	ダーリントン 2SC2435 とコンプリ	
★	〃 1046	〃	〃	〃	−100	−100	−15A	100W (Tc=25°C)	175	−50	−100	3000	−3	−3A										102	ダーリントン 2SC2436 とコンプリ	
	〃 1047	三洋	PA	〃	−180	−160	−80	1 W	150	−1	−120	60~320	−5	−10	−10	10					130 *	3.2		296	2SC2441 とコンプリ	
	〃 1048	東芝	AF	Si. E	−50	−50	−150	200	125	−0.1	−50	70~400	−6	−2	−10	1	NF< 3 dB (−6V, 0.1mA, 1kHz)				>80 *	4		287	2SC2458 とコンプリ	
	〃 1049	〃	〃	〃	−120	−120	−100	200	125	−0.1	−120	200~700	−6	−2	−6	1	NF= 1 dB (−6V, 0.1mA, 1kHz)				100 *	4		287	2SC2459 とコンプリ	
★	〃 1050	〃	PA	〃	−140	−140	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−10	−140	55~240	−5	−1 A	−10	1 A					70 *	220	2 *	102	2SC2460 とコンプリ	○
★	〃 1051	〃	〃	〃	−150	−150	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−10	−150	55~240	−5	−1 A	−10	1 A					60 *	350	2 *	102	2SC2461 とコンプリ	○
	〃 1052	日立	AF	〃	−30	−30	−100	150	150	−0.5	−20	100~500	−12	−2	−12	2					280 *	3.3		176		
	〃 1053	日電	SW	〃	−40	−40	−200	600	150	−0.1	−30	150	−1	−10			t_{on}<70ns, t_{off}<300ns t_{stg}<225ns							138D		
	〃 1054	〃	〃	〃	−60	−40	−600	600	150	−0.02	−50	200	−10	−150			t_{on}<35ns, t_{off}<255ns t_{stg}<225ns							138D		
	〃 1055	〃	〃	〃	−25	−25	−200	600	150	−0.05	−20	150	−1	−2			t_{on}<70ns, t_{off}<300ns t_{stg}<225ns							138D		
	〃 1056	〃	〃	〃	−40	−40	−600	600	150	−0.1	−35	150	−2	−150			t_{on}<35ns, t_{off}<255ns t_{stg}<225ns							138D		
★	〃 1057	〃	RF	〃	−20	−12	−50	300	200	−0.1	−10	90	−10	−15	−10	15	$\|S_{21e}\|^2$=10dB (1GHz) NF=2.4dB (10V, 3mA, 1GHz)				4000 *	1.2		320		
★	〃 1058	〃	〃	〃	−20	−12	−50	250	200	−0.1	−15	60	−10	−10	−10	10	$\|S_{21e}\|^2$=6dB (1GHz) NF=2.3dB (10V, 3mA, 0.56Hz)				2500 *			320		
	〃 1059	〃	SW. Diff	〃	−20	−12	−30	250/unit.	200	−0.1	−15	60	−10	−10			t_{on}<10ns t_{off}<10ns	h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0 ΔV_{OE}<20mV						307B	2素子複合	
★	〃 1060	松下	PA	Si. EP	−80	−80	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−50	−80	90	−5	−1A	−5	500					15 *	170	10	365	2SC2484 とコンプリ	
★	〃 1061	〃	〃	〃	−100	−100	−6A	70W (Tc=25°C)	150	−50	−100	90	−5	−1A	−5	500					20 *	240	10	365	2SC2485 とコンプリ	
★	〃 1062	〃	〃	〃	−120	−120	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−50	−120	90	−5	−1A	−5	500					20 *	290	10	365	2SC2486 とコンプリ	
★	〃 1063	〃	〃	〃	−150	−150	−6A	80W (Tc=25°C)	150			40~280	−5	−2A	−10	500					50 *			102	2SC2487 とコンプリ	
★	〃 1064	〃	〃	〃	−150	−150	−8A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−70	40~280	−5	−2A	−10	500					50 *			102	2SC2488 とコンプリ	
★	〃 1065	〃	〃	〃	−150	−150	−10A	120W (Tc=25°C)	150	−1mA	−70	40~280	−5	−2A	−10	500					50 *			102	2SC2489 とコンプリ	
★	〃 1066	ソニー	LN	Si.EPa	−70	−50	−200	500	120	−0.1	−50	95~420	−3	−10	−10	10					120 *	13		138	2SC2014 とコンプリ	
★	〃 1067	サンケン	PA	Si. EP	−120	−120	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−120	60	−4	−3A	−12	500					50 *	140	40	102		
★	〃 1068	〃	〃	〃	−150	−150	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−150	60	−4	−3A	−12	500					50 *	140	40	102		
	〃 1069	日電	SW	Si. E	−80	−60	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−60	40~200	−5	−3A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							268	2SC2516 とコンプリ	○
	〃 1070	〃																								
★	〃 1071	〃																								
★	〃 1072	富士通	PA	Si. P	−120	−120	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−120	110	−5	−1 A	−10	1 A					60 *	300	1.5 *	102	2SC2522 とコンプリ	○

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1073	富士通	PA	Si. P	−160	−160	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−160	110	−5	−1 A	−10	1 A					60 *	300	1.5 *	102	2SC2523 とコンプリ
★ 〃 1074	〃																							
〃 1075	〃	PA	Si. P	−120	−120	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−120	110	−5	−1 A							60 *			163	2SC2525 とコンプリ
〃 1076	〃	〃	〃	−160	−160	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−160	110	−5	−1 A							60 *			163	2SC2526 とコンプリ
〃 1077	〃	〃	〃	−120	−120	−10A	60W (Tc=25°C)	150	−50	−120	110	−5	−1 A	−10	1 A					60 *	300	1.5 *	268	2SC2527 とコンプリ
〃 1078	〃	〃	〃	−120	−120	−2 A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−120	120	−5	−300	−10	500					140 *	100	12 *	268	2SC2528 とコンプリ
〃 1079	〃	〃	〃	−160	−160	−2 A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−160	120	−5	−300	−10	500					140 *	100	12 *	268	2SC2529 とコンプリ
〃 1080	〃	〃	〃	−40	−40	−500	20W (Tc=25°C)	150	−0.1	−40	150	−5	−10	−10	10					30 *	65	15 *	268	2SC2530 とコンプリ
〃 1081	日立	AF	Si. E	−90	−90	−100	400	150	−0.1	−50	250~800	−12	−2	−12	2					90 *	3.5		138	2SC2543 とコンプリ
〃 1082	〃	〃	〃	−120	−120	−100	400	150	−0.1	−50	250~800	−12	−2	−12	2					90 *	3.5		138	2SC2544 とコンプリ
〃 1083	〃	AF. LN	〃	−60	−60	−100	400	150	−0.1	−50	250~800	−12	−2	−12	2	e_n = 0.5nV/√Hz (6 V, 10mA, 1 kHz)				90 *	3.5		138	2SC2545 とコンプリ
〃 1084	〃	〃	〃	−90	−90	−100	400	150	−0.1	−50	250~800	−12	−2	−12	2	〃				90 *	3.5		138	2SC2546 とコンプリ
〃 1085	〃	〃	〃	−120	−120	−100	400	150	−0.1	−50	250~800	−12	−2	−12	2	〃				90 *	3.5		138	2SC2547 とコンプリ
★ 〃 1086	東芝																							
★ 〃 1087	〃																							
★ 〃 1088	〃																							
★ 〃 1089	〃																							
〃 1090	〃	RF. SW	Si. E	−60	−50	−200	300	175	−0.1	−60	70~400	−1	−10	−10	10	t_{on} = 30ns, t_f = 30ns t_{stg} = 400ns				250 *	4	30	49C	2SC2550 とコンプリ
〃 1091	〃	RF	Si. T	−300	−300	−100	400	150	−0.1	−300	90	−10	−20	−10	20					70 *	6	15	138	2SC2551 とコンプリ
★ 〃 1092	松下	〃	Si. EP	−60	−55	−50	400	150	−0.1	−30	450	−5	−2	−5	20					220 *	8	5	138	2SC2557 とコンプリ
〃 1093	東芝	PA	Si. E	−120	−120	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−50	−120	120	−5	−1 A	−10	1 A					90 *	150	2 *	179	
〃 1094	〃	〃	〃	−140	−140	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−140	55~240	−5	−1 A	−10	1 A					70 *	220	2 *	125	2SC2564 とコンプリ
〃 1095	〃	〃	〃	−160	−160	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−50	−160	55~240	−5	−1 A	−10	1 A					60 *	350	2 *	125	2SC2565 とコンプリ
〃 1096	松下	RF	Si. EP	−70	−50	−2A	1.2W	150	−1	−20	120	−5	−1 A	−5	500					150 *	55	110	222	
★ 〃 1097	ソニー																							
★ 〃 1098	三菱																							
★ 〃 1099	〃																							
★ 〃 1100	〃	AF. RF	Si. E	−50	−50	−200	300	125	−0.1	−50	90~500	−6	−1	−6	10	NF<20dB (f=100Hz, 6 V, 0.3mA)				200 *	7		138B	
★ 〃 1101	〃																							
★ 〃 1102	サンケン	PA	Si. EP	−80	−80	−6A	60W (Tc=25°C)	150	−100	−80	80	−4	−2 A	−12	500					20 *	150	15	324	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SA1103	サンケン	PA	Si.EMe	−100	−100	−7A	70W (Tc=25°C)	150	−100	−100	80	−4	−3A	−12	500					20 *	200	11	324		
★	〃 1104	〃	〃	Si. EP	−120	−120	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−120	80	−4	−3A	−12	500					20 *	300	7	324		
★	〃 1105	〃	〃	Si.TMe	−120	−120	−9A	90W (Tc=25°C)	150	−100	−120	80	−4	−3A	−12	500					20 *	400	8	324		
★	〃 1106	〃	〃	Si. EP	−140	−140	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−140	80	−4	−3A	−12	500					20 *	400	7	324		
★	〃 1107	日電	〃	Si. E	−150	−130	−10A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−130	150	−5	−1A	−5	200					50 *	250	10	340		○
★	〃 1108	〃	〃	〃	−130	−130	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−120	150	−5	−2A	−5	1A					60 *	270	10	340		○
★	〃 1109	〃	〃	〃	−180	−180	−10A	200W (Tc=25°C)	150	−50	−160	90	−5	−2A	−5	1A					60 *	450	10	102	2SC2589 とコンプリ	
	〃 1110	松下	〃	Si. EP	−120	−120	−500	5 W	150			65~330	−10	−150	−10	50					200 *	30		222	2SC2590 とコンプリ	
	〃 1111	〃	〃	〃	−150	−150	−1A	20W (Tc=25°C)	150			65~330	−10	−150	−10	50					200 *	30		268	2SC2591 とコンプリ	
	〃 1112	〃	〃	〃	−180	−180	−1A	20W (Tc=25°C)	150			65~330	−10	−150	−10	50					200 *	30		268	2SC2592 とコンプリ	
★	〃 1113	三菱	Diff	〃	−70	−70	−200	200/unit.	125	−0.1	−50	300	−6	−1	−6	1	300	7.8 k	3.4	19	100 *	24	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	283	2素子複合	
	〃 1114	〃	AF. LN	〃	−70	−70	−200	500	125	−0.1	−70	250~1200	−6	−1	−6	10	V_{NO}<300mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_r=80dB)				150 *	8	2	138B		
	〃 1115	〃	〃	〃	−50	−50	−200	300	125	−0.1	−50	90~800	−6	−1	−6	10	NF<20dB (100Hz, 6 V 0.3mA)				200 *	6.5		175	2SC2603 とコンプリ	
★	〃 1116	サンケン	PA	〃	−200	−200	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−100	−200	>30	−4	−5 A	−12	500	t_r=0.3μs, t_f=0.2μs t_{stg}=0.9μs				20 *			102	2SC2607 とコンプリ	
★	〃 1117	〃	〃	〃	−200	−200	−17A	200W (Tc=25°C)	150	−100	−200	>20	−4	−8 A	−12	1 A	t_r=0.6μs, t_f=0.2μs t_{stg}=0.9μs				20 *			102	2SC2608 とコンプリ	
★	〃 1118	東芝																								
★	〃 1119	〃																								
★	〃 1120	〃	RF	Si. E	−35	−20	−5A	10W (Tc=25°C)	150	−0.1	−35	200	−2	−500	−2	500					170 *	62	10 *	342	2SC2270 とコンプリ	
	〃 1121	日立	〃	〃	−35	−35	−500	150	150	−0.5	−20	60~320	−3	−10	−6	1					50 *	7	12 *	176	2SC2618 とコンプリ	
	〃 1122	〃	AF	〃	−55	−55	−100	150	150	−0.5	−30	160~800	−12	−2										176		
	〃 1123	松下	〃	Si. EP	−150	−150	−50	750	150	−1	−100	65~450	−5	−10	−10	10	V_{NO}=150mV (−10V, −1mA, R_G=100kΩ, G_v=80dB)				200 *	<5		138	2SC2631 とコンプリ	
	〃 1124	〃	〃	〃	−150	−150	−50	1 W	150	−1	−100	65~450	−5	−10	−10	10	V_{NO}=150mV (−10V, −1mA, R_G=100kΩ, G_v=80dB)				200 *	<5		294	2SC2632 とコンプリ	
	〃 1125	〃	〃	〃	−150	−150	−50	1.5W	150	−1	−100	65~450	−5	−10							200 *	<5		268	2SC2633 とコンプリ	
	〃 1126	日立	SW	Si. T	−650	−600	−100	750	150	I_{CEO} −5	−500	35~200	−20	−20	−10	10					15 *	<25		84B	2SC2635 とコンプリ	
	〃 1127	松下	AF	Si. EP	−60	−50	−100	400	150	−0.1	−10	180~700	−5	−2										138	2SC2634 とコンプリ	
	〃 1128	〃	〃	〃	−25	−20	−500	600	135	−0.1	−25	65~220	−2	−500	−10	50					150 *	15		138	2SC1788 とコンプリ	
	〃 1129	日電	PA. SW	Si. E	−30	−30	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−30	100	−1	−3A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							268		
★	〃 1130																									
★	〃 1131																									
★	〃 1132																									

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1133	松下	PA	Si. EP	−200	−150	−2A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−200	60~200	−10	−400										268	2SC2660 とコンプリ ○
★ 〃 1134																								
★ 〃 1135	サンケン	PA	Si.EMe	−80	−80	−4A	55W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	90	−4	−1A	−10	200					10 *	100	14	324	
〃 1136	ローム	RF. LN	Si. EP	−120	−120	−100	300	125	−0.5	−100	270	−6	−2	−6	2	NF=0.2dB (−6V, −0.1mA, 100Hz)				90 *	4	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138	2SC2674 とコンプリ
〃 1137	〃	〃	〃	−80	−80	−100	300	125	−0.5	−75	270	−6	−2	−6	2	NF=0.2dB (−6V, −0.1mA, 100Hz)				90 *	4	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138	2SC2675 とコンプリ
〃 1138	日電	RF. LN	Si. E	−80	−80	−10	500	125	−0.1	−70	400	−6	−1	−6	1	NF=1.5dB (6V, 1mA, 1kHz)				180 *	1.4	$C_c r_{bb'}$ 92ps	278	
★ 〃 1139	〃																							
★ 〃 1140	〃																							
〃 1141	〃	PA	Si. T	−115	−115	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−80	140	−2	−1A	−2	1A					90 *	390		162	2SC2681 とコンプリ
〃 1142	〃	〃	Si. E	−180	−180	−100	8W (Tc=25°C)	150	−1	−180	200	−5	−10	−10	20					160 *	5.8	27 *	225	
〃 1143	三菱	RF. AF	Si. EP	−20	−20	−50	200	125	−0.1	−15	250	−6	−1	−6	1					100 *	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	175	
★ 〃 1144	東芝	RF	Si. E	−150	−150	−50	10W (Tc=25°C)	150	−0.1	−150	150	−5	−10	−10	10					200 *	2.5	50	342	
〃 1145	〃	〃	〃	−150	−150	−50	800	150	−0.1	−150	160	−5	−10	−10	10					200 *	2.5	70 *	241	2SC2705 とコンプリ
〃 1146	〃	PA	〃	−140	−140	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−140	120	−5	−1A	−10	1A					70 *	220	2 *	179	
〃 1147	〃	〃	〃	−180	−180	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−50	−160	120	−5	−1A	−10	1A					60 *	350	2 *	102	2SC2707 とコンプリ
★ 〃 1148	〃																							
★ 〃 1149	〃																							
〃 1150	〃	AF	Si. E	−35	−30	−800	300	125	−0.1	−30	100~320	−1	−100	−5	10					120 *	19		287	2SC2710 とコンプリ
〃 1151	日電	〃	〃	−60	−50	−100	250	125	−0.1	−60	200	−6	−1	−6	10	NF=6dB (−6V, −0.3mA, f=100Hz)				180 *	4.5		138	2SC2718 とコンプリ
〃 1152	〃	RF. SW	〃	−80	−80	−300	600	150	−0.1	−80	200	−1	−50	−6	10	t_{on}=50ns, t_{off}=450ns t_{stg}=400ns				100 *	13		138	2SC2719 とコンプリ
〃 1153	〃	〃	〃	−60	−40	−500	600	150	−0.1	−40	140	−2	−150	−10	20	t_{on}<35ns, t_{off}<255ns t_{stg}<225ns				400 *	5		138D	2SC2720 とコンプリ
〃 1154	〃	〃	〃	−60	−60	−700	1W	150	−0.1	−60	200	−1	−100	−6	10	t_{on}=65ns, t_{off}=540ns t_{stg}=490ns				120 *	25		278	2SC2721 とコンプリ
★ 〃 1155	三菱	Diff.	〃	−100	−100	−100	200/unit.	125	−0.1	−100	600	−6	−1	−6	1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0 ΔV_{BE}<10mV				100 *	3		283	2素子複合
〃 1156	日電	SW	Si. T	−400	−400	−500	10W (Tc=25°C)	150	−10	−400	80	−5	−100			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs							225	
★ 〃 1157	東芝																							
★ 〃 1158	〃	RF. AF	Si. E	−80	−80	−100	400	125	−0.1	−80	400	−6	−2	−10	2					200 *	3	30	138	2SC2868 とコンプリ
★ 〃 1159	〃																							
〃 1160	〃	RF	Si. E	−20	−10	−2A	900	150	−10	−20	240	−1	−500	−1	500					150 *	60	11	241	2SC2500 とコンプリ
〃 1161	〃	〃	Si. EP	−15	−8	−30	200	125	−0.1	−5	50	−5	−10	−5	10	NF=3.5dB (−5V, −3mA, 1GHz)				3500 *	0.95	55 *	138C	
〃 1162	〃	AF	Si. E	−50	−50	−150	150	125	−0.1	−50	250	−6	−2	−10	1					150 *	4	30	176	2SC2712 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SA1163	東芝	AF. RF. LN	Si. E	−120	−120	−100	150	125	−0.1	−120	350	−6	−2	−6	1	350	12k	1.2	13	100*	3	18	176	2SC2713とコンプリ
	〃 1164	〃	RF. SW	〃	−35	−30	−100	200	125	−0.1	−35	200	−12	−2	−12	10	t_{on}<60ns, t_f<140ns t_{stg}<500ns				400*	2.5	40	138	2SC2754とコンプリ
★	〃 1165	日電																			↘				
★	〃 1166	〃	PA	Si. E	−160	−160	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−50	−150	150	−5	−2A	−5	1A					60*	320	10	340	○
★	〃 1167	三菱																							
★	〃 1168	〃																							
★	〃 1169	サンケン	PA	Si. EP	−200	−200	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−100	−200	80	−4	−5A	−12	500					20*	400	7	256	
★	〃 1170	〃	〃	〃	−200	−200	−17A	200W (Tc=25°C)	150	−100	−200	70	−4	−8A	−12	1A					20*	500	7	256	
	〃 1171	日立	RF	Si. E	−90	−90	−50	150	150	−0.5	−75	400	−12	−2	−12	2					200*	1.6	12*	176	2SC2775とコンプリ
	〃 1172																								
	〃 1173	日電	AF	Si. E	−140	−140	−50	2W (セラミック基板使用)	150	−0.1	−140	200	−10	−10	−10	10					80*	2.5		336	2SC2780とコンプリ
	〃 1174	〃	RF. LN	〃	−60	−60	−50	300	125	−0.1	−50	400	−6	−1	−6	1	NF=1dB (6V, 1mA, 1kHz)				90*	2	$C_c r_{bb'}$ 100ps	42	
	〃 1175	〃	AF	〃	−60	−50	−100	250	150	−0.1	−60	200	−6	−1	−6	10	NF=6dB (−6V, −0.3mA, f=100Hz)				180*	4.5		42	2SC2785とコンプリ
★	〃 1176	〃																							
★	〃 1177	三洋	RF	Si. EP	−30	−20	−30	150	125	−0.1	−10	60~320	−6	−1	−6	1	G_{pe}=22dB, NF=2.5dB (−6V, −1mA, 100MHz)				230*	C_{re} 1.1	$C_c r_{bb'}$ 11ps	92	
	〃 1178	松下	〃	〃	−150	−150	−1A	20W (Tc=25°C)	150	−10	−100	160	−10	−150	−10	50					200*	30	50	222	2SC2803とコンプリ
	〃 1179	三洋	AF	〃	−55	−50	−150	200	125	−0.1	−35	100~560	−6	−1	−6	1					180*	7		176	
	〃 1180	富士通	SW	〃	−180	−180	−10A	100W (Tc=25°C)	175	−50	−180	60	−5	−1.5A			t_r<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<0.5μs							102	○
★	〃 1181	〃																							
	〃 1182	東芝	RF. AF	Si. E	−35	−30	−500	150	125	−0.1	−35	120	−1	−100	−6	20					200*	13	20	176	2SC2859とコンプリ
★	〃 1183	〃	PA	〃	−120	−120	−7A	70W (Tc=25°C)	150	−50	−120	15000	−5	−1A	−5	1A					50*	140	10	203	ダーリントン
★	〃 1184	〃	RF	〃	−120	−120	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−0.1	−120	150	−5	−100	−5	100					120*	30	3*	342	2SC2824とコンプリ
	〃 1185	松下	PA	Si. EP	−50	−50	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−50	60~320	−5	−1A	5	−500					100*	250		365	
	〃 1186	サンケン	〃	〃	−150	−150	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−150	60	−4	−3A	−12	1A					60*	110	20	324	2SC2837とコンプリ
★	〃 1187	〃	〃	〃	−150	−150	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−100	−150	60	−4	−3A	−12	1A					60*	110	20	256	
	〃 1188	日立	RF. AF	Si. E	−90	−90	−100	400	150	−0.1	−70	450	−12	−2	−6	10					130*	3.2	30	138	2SC2853とコンプリ
	〃 1189	〃	〃	〃	−120	−120	−100	400	150	−0.1	−70	400	−12	−2	−6	10					130*	3.2	30	138	2SC2854とコンプリ
	〃 1190	〃	RF. LN	〃	−90	−90	−100	400	150	−0.1	−70	450	−12	−2	−6	10	NF=0.15dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				130*	3.2	30	138	2SC2855とコンプリ
	〃 1191	〃	〃	〃	−120	−120	−100	400	150	−0.1	−70	400	−12	−2	−6	10	NF=0.15dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				130*	3.2	30	138	2SC2856とコンプリ
★	〃 1192																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SA1193	日立	AF	Si. E	−60	−60	−500	900	150	−1	−60	5000	−3	−250			t_{on}<0.5μs, t_{off}<0.5μs t_{stg}<1μs							251	ダーリントン
〃 1194	〃	〃	〃	−60	−60	−1A	8 W (Tc=25°C)	150	−1	−60	3000	−3	−500			t_{on}<1.5μs, t_{off}<1.5μs t_{stg}<1μs							160	ダーリントン
〃 1195	東芝	RF	〃	−160	−160	−1.5A	15W (Tc=25°C)	175	−1	−150	160	−5	−200	−5	200					50 *	27	10	178	2SC2483 とコンプリ
★ 〃 1196	日立	SW	Si. T	−400	−360	−100	10W (Tc=25°C)	150	−1	−350	120	−20	−20			t_{on}<2μs, t_{off}<10μs t_{stg}<8μs							245	
〃 1197	〃	〃	Si. E	−60	−60	−1A	8 W (Tc=25°C)	150	−1	−60	3000	−3	−500			t_{on}<1.5μs, t_{off}<1.5μs t_{stg}<1μs							245	
〃 1198	ローム	RF. AF	Si. EP	−80	−80	−50	400	125	−0.5	−75	390	−6	−2	−12	2					140 *	3.4	$C_c r_{bb'}$ 130ps	138	
〃 1199	〃	〃	〃	−50	−40	−700	400	125	−0.5	−30	270	−6	−10	−6	10					100 *	12	$C_c r_{bb'}$ 200ps	138	2SC2872 とコンプリ
〃 1200	東芝	〃	Si. T	−150	−150	−50	500	150	−0.1	−150	110	−5	−10	−5	10					120 *	4	10	336	2SC2880 とコンプリ
〃 1201	〃	〃	Si. E	−120	−120	−800	500	150	−0.1	−120	140	−5	−100	−5	100					120 *	27	3 *	336	2SC2881 とコンプリ
〃 1202	〃	〃	〃	−80	−80	−400	500	150	−0.1	−80	140	−2	−50	−10	10					120 *	14	5	336	2SC2882 とコンプリ
〃 1203	〃	〃	〃	−30	−30	−1.5A	500	150	−0.1	−30	180	−2	−500	−2	500					120 *	40	5 *	336	2SC2883 とコンプリ
〃 1204	〃	〃	〃	−35	−30	−800	500	150	−0.1	−30	200	−1	−100	−5	10					120 *	19	25	336	2SC2884 とコンプリ
〃 1205	サンケン	PA	Si. EP	−70	−50	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−70	100	−0.5	−5A	−12	3A					20 *	650	7	324	
〃 1206	日電	SW	Si. E	−15	−15	−50	600	150	−0.1	−8	80	−1	−10	−10	10	t_{on}<20ns, t_{off}<40ns t_{stg}<40ns				1800*	2		138D	2SC2901 とコンプリ
〃 1207	三洋	RF. AF	Si. TP	−180	−160	−70	600	150	−0.1	−80	180	−5	−10	−10	10					150 *	2.5	$C_c r_{bb'}$ 40ps	138	2SC2909 とコンプリ
〃 1208	〃	AF. SW	〃	−180	−160	−70	900	150	−0.1	−80	180	−5	−10	−10	10	t_{on}=0.1μs, t_f=0.2μs t_{stg}=1μs				150 *	2.5		294	2SC2910 とコンプリ
〃 1209	〃	〃	〃	−180	−160	−140	10W (Tc=25°C)	150	−0.1	−80	180	−5	−10	−10	10	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_{stg}=1.5μs				150 *	4		296	2SC2911 とコンプリ
〃 1210	〃	〃	〃	−200	−200	−140	10W (Tc=25°C)	150	−0.1	−160	180	−5	−10	−10	10	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_{stg}=1.5μs				150 *	4		296	2SC2912 とコンプリ
★ 〃 1211	東芝	SW	Si. E	−35	−30	−100	200	125	−0.1	−35	200	−12	−2	−12	10	t_{on}<100ns, t_f<200ns t_{stg}<1μs				400 *	2.5	70	287	
★ 〃 1212	〃																							
〃 1213	〃	RF. AF	Si. E	−50	−50	−2A	500	150	−1	−50	130	−2	−500	−2	500					120 *	40	5 *	336	2SC2873 とコンプリ
★ 〃 1214	〃	RF	〃	−60	−60	−2A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−60	120	−2	−150	−2	150					35 *	45	20	342	
〃 1215	サンケン	PA	Si. EP	−160	−160	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−100	−160	80	−4	−5A	−12	2A					50 *	400	10	256	2SC2921 とコンプリ
〃 1216	〃	〃	〃	−180	−180	−17A	200W (Tc=25°C)	150	−100	−180	70	−4	−8A	−12	2A					40 *	500	8	256	2SC2922 とコンプリ
★ 〃 1217	東芝	RF	Si. E	−40	−40	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−0.1	−40	150	−2	−500	−2	500					100 *	35	10	342	2SC2877 とコンプリ
〃 1218	日電	SW	〃	−60	−60	−600	360	200	−0.01	−50	200	−10	−150			t_{on}<45ns, t_{off}<300ns t_{stg}<290ns							49C	
★ 〃 1219	〃	AF	〃	−60	−50	−100	250	125	−0.1	−60	200	−6	−1	−6	10	NF=6 dB (6 V, 0.3mA, 100Hz)				180 *	45		42	2SC2947 とコンプリ
〃 1220	〃	PA	〃	−120	−120	−1.2A	20W (Tc=25°C)	150	−50	−110	150	−5	−300	−5	300					160 *	29	10	225	
〃 1221	〃	RF. PA	〃	−160	−140	−500	1 W	150	−0.2	−100	150	−2	−100	−10	20					45 *	24	10	278	2SC2958 とコンプリ
〃 1222	〃	〃	〃	−160	−160	−500	1 W	150	−0.2	−100	150	−2	−100	−10	20					45 *	24	10	278	2SC2959 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★ 2SA1223	日電	RF	Si. E	−20	−12	−50	300	200	−0.1	−10	90	−10	−15	−10	15	$\lvert S_{21e}\rvert^2$=10dB (10V, 20mA, 1GHz) NF=2.4dB (10V, 3mA, 1GHz)				4000*	1.2		314	
★ 〃 1224	〃	SW	〃	−40	−25	−250	800	200	−0.1	−20	75	−10	−50	−10	50	t_r<10ns, t_f<10ns t_{stg}<40ns				2500*	2.1		85B	
〃 1225	東芝	RF	〃	−160	−160	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−120	120	−5	−100	−10	100					100*	30	4*	344	2SC2983とコンプリ
〃 1226	日電	〃	〃	−40	−40	−30	200	150	−0.1	−40	100	−10	−1	−10	1	NF=3.5dB (f=1 MHz)				400*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176	
〃 1227	〃	PA	〃	−140	−140	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−140	130	−5	−2A	−5	1 A					60*	280	10	162	2SC2987とコンプリ ○
〃 1228	〃	RF	〃	−20	−12	−50	250	200	−0.1	−10	90	−10	−15	−10	15	$\lvert S_{21e}\rvert^2$=10dB (1GHz) NF=3.2dB (10V, 3mA, 1GHz)				4000*			50C	
〃 1229	〃	Diff	〃	−20	−12	−50	300/unit	200	−0.1	−10	90	−10	−15	−10	15	h_{FE1}/h_{FE2}=0.6～1.0 ΔV_{BE}<20mV				4000*	1	20*	307B	2素子複合
〃 1230	〃	RF	〃	−15	−10	−50	300	200	−0.1	−10	90	−6	−20	−5	20	$\lvert S_{21e}\rvert^2$=12dB (1GHz) NF=1.8dB (10V, 3mA, 1GHz)				8000*			320	
〃 1231	〃	Diff	〃	−15	−10	−50	250/unit	200	−0.1	−10	90	−6	−20	−6	20	h_{FE1}/h_{FE2}=0.6～1.0 ΔV_{BE}<20mV				8000*	0.4	17*	307B	2素子複合
〃 1232	〃	PA	〃	−130	−130	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−120	130	−5	−2A	−5	1 A					60*	260	10	162	
★ 〃 1233	日立	SW	Si. T	−400	−360	−100	10W (Tc=25°C)	150	−10	−400	80	−20	−20			t_{on}< 2 μs, t_{off}< 5 μs t_{stg}< 1 μs							245	
★ 〃 1234	〃																							
〃 1235	三菱	RF. AF	Si. EP	−50	−50	−200	150	125	−0.1	−50	250	−6	−1	−6	1	250	7 k	1	18	200*	5.5	$C_c r_{bb'}$ 50ps	176	2SC3052とコンプリ
★ 〃 1236	富士通	SW	〃	−400	−400	−2A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−400	40	−5	−100			t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 3 μs							268	
〃 1237	三洋	Diff	〃	−55	−50	−150	250/unit	150	−0.1	−35	250	−6	−1	−6	1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.85～1.0 ΔV_{BE}<10mV				100*	5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	355	2素子複合
〃 1238	〃	〃	〃	−55	−50	−150	250/unit	150	−0.1	−35	250	−6	−1	−6	1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.85～1.0 ΔV_{BE}<10mV				100*	5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	355	2素子複合
〃 1239	〃	〃	〃	−130	−120	−50	250/unit	150	−0.1	−80	250	−6	−1	−6	1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.85～1.0 ΔV_{BE}<10mV				110*	2	$C_c r_{bb'}$ 40ps	355	2素子複合
〃 1240	〃	〃	〃	−130	−120	−50	250/unit	150	−0.1	−80	250	−6	−1	−6	1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.85～1.0 ΔV_{BE}<10mV				110*	2	$C_c r_{bb'}$ 40ps	355	2素子複合
〃 1241	東芝	SW	Si. E	−50	−50	−2A	1 W	150	−1	−50	120	−2	−500	−2	500	t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs				100*	40	20	344	
〃 1242	〃	RF	〃	−35	−20	−5A	20W (Tc=25°C)	150	−0.1	−35	200	−2	−500	−2	500					170*	62	15	344	
〃 1243	〃	〃	〃	−30	−30	−3A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−20	150	−2	−500	−2	500					100*	40	10	344	2SC3073とコンプリ
〃 1244	〃	AF. PA. SW	〃	−60	−50	−5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−50	130	−1	−1A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							344	2SC3074とコンプリ
〃 1245	〃	RF	〃	−15	−8	−30	150	125	−0.1	−5	50	−5	−10	−5	10	NF=2.5dB (500MHz)				4000*	0.75	55*	176	
〃 1246	三洋	AF. RF	Si. EP	−60	−50	−150	400	150	−0.1	−40	250	−6	−1	−6	1					100*	4.2	$C_c r_{bb'}$ 170ps	138	2SC3114とコンプリ
〃 1247	日電	RF. LN	Si. E	−120	−120	−50	200	150	−0.1	−120	500	−6	−1	−6	1	NF=1.5dB (1 kHz)				80*	2.2	50*	176	
〃 1248	三洋	RF	Si. EP	−180	−160	−700	10W (Tc=25°C)	150	−0.1	−120	250	−5	−100	−10	50					120*	11	$C_c r_{bb'}$ 30ps	296	2SC3116とコンプリ
〃 1249	〃	〃	〃	−180	−160	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−120	250	−5	−100	−10	50					120*	22	$C_c r_{bb'}$ 60ps	296	2SC3117とコンプリ
〃 1250	富士通	SW	〃	−200	−200	−8A	30W (Tc=25°C)	175	−10	−150	20	−1	−5A			t_r<300ns, t_f<200ns t_{stg}<250ns							99	
〃 1251	〃	〃	〃	−400	−360	−150	350	150	−10	−400	70	−10	−20			t_{on}<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 2 μs							49C	
〃 1252	三洋	AF	〃	−60	−50	−150	200	125	−0.1	−40	100～560	−6	−1	−6	1					100*	3.5		176	2SC3134とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1252A																								
〃 1253	三洋	RF. AF	Si. EP	−60	−50	−200	250	150	−0.1	−40	250	−6	−1	−6	1					100*	4	$C_c r_{bb'}$ 170ps	92	2SC3135 とコンプリ
〃 1254	松下	〃	〃	−30	−20	−30	400	135	−0.1	−10	100	−10	−1	−10	1					300*	2	10	151	2SC2206 とコンプリ
〃 1255	東芝	RF	Si. T	−200	−200	−50	150	125	−0.1	−200	120	−3	−10	−10	2					100*	3	20	176	
〃 1256	三洋	RF. Conv Mix. Osc	Si. EP	−30	−20	−30	150	125	−0.1	−10	120	−6	−1	−6	1	G_{pe}=22dB (6V, 1mA, 100MHz)				230*	1.8	$C_c r_{bb'}$ 11ps	176	
〃 1257	〃	RF	〃	−180	−160	−80	200	125	−0.1	−120	150	−5	−10	−10	10	t_{on}=0.15μs, t_f=0.15μs t_{stg}=0.95μs				130*	2.4	$C_c r_{bb'}$ 12ps	176	2SC3143 とコンプリ
〃 1258	〃	AF. PA	〃	−70	−60	−3A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−1.5A	−5	1.5A	t_{on}=0.3μs, t_f=0.2μs t_{stg}=1.2μs				200*			268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1259	〃	〃	〃	−70	−60	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−2.5A	−5	2.5A					200*			268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1260	〃	〃	〃	−70	−50	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−3.5A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1261	日電	SW	Si. E	−100	−100	−10A	60W (Tc=25°C)	150	−10	−100	80	−5	−3A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							370	
〃 1262	サンケン	PA	Si. EP	−60	−60	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−60	100	−4	−1A	−12	200	t_{on}=0.25μs, t_f=0.25μs t_{stg}=0.75μs				15*			298	2SC3179 とコンプリ
〃 1263	東芝	〃	Si. T	−80	−80	−6A	60W (Tc=25°C)	150	−5	−80	95	−5	−1A	−5	1A					30*	290	20	203	2SC3180 とコンプリ
〃 1264	〃	〃	〃	−120	−120	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−5	−120	95	−5	−1A	−5	1A					30*	420	15	203	2SC3181 とコンプリ
〃 1265	〃	〃	〃	−140	−140	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−5	−140	95	−5	−1A	−5	1A					30*	480	10	203	2SC3182 とコンプリ
〃 1266	韓国電子	RF. AF	Si. EP	−50	−50	−150	400	125	−0.1	−50	185	−6	−2	−10	1	NF=1dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				130*	4	30	138	2SC3198 とコンプリ
〃 1267	〃	〃	〃	−50	−50	−150	200	125	−0.1	−50	185	−6	−2	−10	1	NF=1dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				130*	4	30	287	2SC3199 とコンプリ
〃 1268	〃	RF.AF.LN	〃	−120	−120	−100	300	125	−0.1	−120	415	−6	−2	−6	1	NF<6dB (6V, 0.1mA, 10Hz)				100*	4	11	138	2SC3200 とコンプリ
〃 1269	〃	RF. AF	〃	−120	−120	−100	200	125	−0.1	−120	415	−6	−2	−6	1	NF=1dB (6V, 1mA, 1kHz)				100*	4	11	287	2SC3201 とコンプリ
〃 1270	〃	〃	〃	−35	−30	−500	500	150	−0.1	−35	150	−1	−100	−6	20					200*	13	$C_c r_{bb'}$ 70ps	138	2SC3202 とコンプリ
〃 1271	〃	〃	〃	−35	−30	−800	600	150	−0.1	−35	180	−1	−100	−5	10					120*	19	5	138	2SC3203 とコンプリ
〃 1272	〃	〃	〃	−35	−30	−800	300	125	−0.1	−35	180	−1	−100	−5	10					120*	19	5	287	2SC3204 とコンプリ
〃 1273	〃	RF. PA	〃	−30	−30	−2A	1W	150	−0.1	−30	185	−2	−500	−2	500					120*	48	5	241	2SC3205 とコンプリ
〃 1274	〃	〃	〃	−80	−80	−400	800	150	−0.1	−50	150	−2	−50	−10	10					100*	14	4	241	2SC3227 とコンプリ
〃 1275	〃	〃	〃	−160	−160	−1A	900	150	−1	−150	190	−5	−200	−5	200					50*	25	4	241	2SC3228 とコンプリ
〃 1276	〃	〃	〃	−30	−30	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−20	110	−2	−500	−2	500					100*	40	6	268	2SC3230 とコンプリ
★ 〃 1277	東芝	RF	Si. E	−30	−30	−3A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−20	150	−2	−500	−2	500					100*	40	10*	51	2SC3237 とコンプリ
★ 〃 1278	〃	〃	〃	−160	−160	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−160	150	−2	−100	−2	100					100*	30	15*	51	2SC3238 とコンプリ
★ 〃 1279	〃	SW	〃	−60	−50	−5A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−60	130	−1	−1A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<5μs							51	2SC3239 とコンプリ
★ 〃 1280	〃	RF	Si. T	−150	−150	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−120	75	−10	−500	−10	500					4*	55	25	51	2SC3234 とコンプリ
〃 1281	三菱	RF. AF PA	Si. EP	−180	−180	−100	900	150	−0.5	−100	150	−10	−10	−10	20					130*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 22ps	6	2SC3248 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1282	三菱	RF. AF. PA	Si. EP	−20	−16	−2A	900	150	−0.2	−16	300	−4	−100	−2	10					80 *	42	$C_c r_{bb'}$ 250ps	6	2SC3242 とコンプリ ○
〃 1283	〃	〃	〃	−60	−60	−1A	900	150	−0.2	−50	200	−4	−100	−2	10					85 *	22	$C_c r_{bb'}$ 65ps	6	2SC3243 とコンプリ
〃 1284	〃	〃	〃	−100	−100	−500	900	150	−0.5	−50	150	−10	−10	−10	10					130 *	11	$C_c r_{bb'}$ 30ps	6	2SC3244 とコンプリ
〃 1285	〃	〃	〃	−120	−120	−100	900	150	−0.1	−100	400	−10	−10	−10	10					200 *	3.5	$C_c r_{bb'}$ 40ps	6	2SC3245 とコンプリ ○
〃 1286	〃	〃	〃	−30	−20	−1.5A	900	150	−0.1	−20	700	−6	−500	−10	10					90 *	37	$C_c r_{bb'}$ 350ps	6	2SC3246 とコンプリ
〃 1287	〃	〃	〃	−50	−50	−1A	900	150	−0.1	−40	700	−6	−500	−10	10					90 *	30	$C_c r_{bb'}$ 350ps	6	2SC3247 とコンプリ
〃 1288	三洋	SW	〃	−80	−60	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−60	170	−2	−1A	−5	1 A	t_{on}<0.1μs, t_f<0.2μs t_{stg}<0.7μs				100 *			268	
〃 1289	〃	〃	〃	−80	−60	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	170	−2	−1A	−5	1 A	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_{stg}=0.5μs				100 *			268	2SC3253 とコンプリ
〃 1290	〃	〃	〃	−80	−60	−7A	35W (Tc=25°C)	150	−100	−40	170	−2	−1A	−5	1 A	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_{stg}=0.5μs				100 *			268	2SC3254 とコンプリ
〃 1291	〃	〃	〃	-80	−60	−10A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	170	−2	−1A	−5	1 A	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_{stg}=0.5μs				100 *			268	2SC3255 とコンプリ
〃 1292	〃	〃	〃	−80	−60	−15A	70W (Tc=25°C)	150	−100	−60	170	−2	−1A	−5	1 A	t_{on}<0.1μs, t_f<0.2μs t_{stg}<0.7μs				100 *			346	2SC3256 とコンプリ
〃 1293	東芝	〃	Si. E	−100	−80	−5A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−80	150	−1	−1A			t_{on}<0.2μs, t_f<0.2μs t_{stg}< 2 μs							268	
〃 1294	サンケン	PA	Si. EP	−230	−230	−15A	130W (Tc=25°C)	150	−100	−230	70	−4	−5A	−12	2 A					35 *	500	10	324	2SC3263 とコンプリ
〃 1295	〃	〃	〃	−230	−230	−17A	200W (Tc=25°C)	150	−100	−230	70	−4	−5A	−12	2 A					35 *	500	10	256	2SC3264 とコンプリ
〃 1296	東芝	RF	〃	−30	−30	−2A	750	150	−0.1	−30	200	−2	−100	−2	500					120 *	40	5 *	138	2SC3266 とコンプリ
〃 1297	〃	〃	〃	−30	−30	−2A	400	150	−0.1	−30	200	−2	−100	−2	100					120 *	40	5 *	287	
〃 1298	〃	RF. AF	〃	−30	−25	−800	200	150	−0.1	−30	200	−1	−100	−5	10					120 *	13	25	176	2SC3265 とコンプリ
〃 1299	三菱	RF.AF.LN	〃	−50	−50	−200	300	125	−0.1	−50	250	−6	−1	−10	10	NF=0.5dB (−6V, −0.3mA, 1 kHz)				200 *	5.5	$C_c r_{bb'}$ 50ps	175	2SC1310 とコンプリ
〃 1300	東芝	RF	Si. E	−20	−10	−2A	750	150	−0.1	−20	300	−1	−500	−1	500					150 *	60	11	138	2SC3279 とコンプリ
〃 1301	〃	PA	Si. T	−160	−160	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−10	−160	100	−5	−1A	−5	1 A					30 *	500	10	152	2SC3280 とコンプリ
〃 1302	〃	〃	〃	−200	−200	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−10	−200	100	−5	−1A	−5	1 A					30 *	600	10	152	2SC3281 とコンプリ
〃 1303	サンケン	PA	Si. EP	−150	−150	−14A	125W (Tc=25°C)	150	−100	−150	80	−4	−5A	−12	2 A					50 *	400	10	324	2SC3284 とコンプリ
〃 1304	東芝	RF	Si. T	−150	−150	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−120	75	−10	−500	−10	.500					4 *	55	25	381	
〃 1305	〃	PA	Si. E	−30	−30	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−30	130	−2	−500	−2	500					100 *	40	10	381	2SC3297 とコンプリ
〃 1306	〃	〃	〃	−160	−160	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−160	130	−5	−100	−10	100					100 *	30	4 *	381	2SC3298 とコンプリ
〃 1307	〃	SW	〃	−60	−50	−5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−50	120	−1	−1A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 3 μs							381	
★ 〃 1308	〃	〃	〃	−100	−80	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−1	−80	150	−1	−1A			t_{on}<0.25μs, t_f<0.2μs t_{stg}< 2 μs							51	2SC3308 とコンプリ
〃 1309	松下	RF	Si. EP	−25	−25	−100	300	125	−1	−10	250	−10	−2	−10	1					80 *	2.7	40	376	
〃 1310	〃	RF.AF.LN	〃	−55	−55	−50	300	125	−0.1	−10	400	−5	−2	−5	2	NF= 1 dB (−10V, −1mA, 1 kHz)				120 *	6	40	376	2SC3312 とコンプリ
★ 〃 1311	東芝	〃	Si. E	−60	−50	−150	200	150	−0.1	−60	200	−6	−2	−10	1	NF= 1 dB (−6V, −1mA, 1 kHz)				150 *	4	30	176	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1312	東芝	RF. AF. LN	Si. E	−120	−120	−100	200	150	−0.1	−120	400	−6	−2	−6	1	NF= 0.2dB (−6V, −1mA, 1kHz)				100*	4	18	176	2SC3324 とコンプリ
〃 1313	〃	RF. AF	〃	−50	−50	−500	200	150	−0.1	−50	120	−1	−100	−6	20					200*	13	20	176	2SC3325 とコンプリ
〃 1314	〃	RF	〃	−20	−10	−2A	500	150	−10	−20	240	−1	−500	−1	500					140*	50	11	336	
〃 1315	〃	RF. SW	〃	−80	−80	−2A	900	150	−1	−80	120	−2	−500	−2	500	t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs				100*	40		241	
〃 1316	〃	RF. AF. LN	〃	−80	−80	−100	400	125	−0.1	−80	400	−6	−1	−6	1	NF=0.2dB (−6V, −0.2mA, 1kHz)				50*	6.5	2	138	2SC3329 とコンプリ
〃 1317	三洋	RF. AF	Si. EP	−60	−50	−200	300	150	−0.1	−40	300	−6	−1	−6	10					200*	3		92	2SC3330 とコンプリ
〃 1318	〃	〃	〃	−60	−50	−200	600	150	−0.1	−40	300	−6	−1	−6	10					200*	3		138	2SC3331 とコンプリ
〃 1319	〃	RF	〃	−180	−160	−700	700	150	−0.1	−120	250	−5	−100	−10	50					120*	11	$C_c r_{bb'}$ 30ps	138	2SC3332 とコンプリ
〃 1320	東芝	〃	Si. T	−250	−250	−50	600	150	−0.1	−200	80	−20	−25	−10	10					100*	2.2	25	138	2SC3333 とコンプリ
〃 1321	〃	〃	〃	−250	−250	−50	900	150	−0.1	−200	80	−20	−25	−10	10					100*	2.2	25	241	
★ 〃 1322	〃	〃	〃	−250	−250	−50	1.2W	150	−0.1	−200	80	−20	−25	−10	10					100*	2.5	25	342	
〃 1323	松下	〃	Si. EP	−30	−20	−30	300	125	−0.1	−10	100	−10	−1	−10	1					300*	1.5	30	376	
★ 〃 1324	東芝	RF. AF	Si. E	−50	−50	−150	200	150	−0.1	−50	250	−6	−2	−10	1					150*	4	30	176A	2SC3339 とコンプリ
★ 〃 1325	〃	〃	〃	−120	−120	−100	200	150	−0.1	−120	350	−6	−2	−6	1					100*	4	18	176A	2SC3340 とコンプリ
★ 〃 1326	〃	〃	〃	−35	−30	−500	200	150	−0.1	−35	120	−1	−100	−6	20					200*	13	20	176A	2SC3341 とコンプリ
〃 1327	〃	RF	〃	−50	−20	−10A	20W (T_c=25°C)	150	−1	−50	200	−2	−1A	−2	1A					50*	400	5	381	
〃 1328	〃	SW	〃	−60	−50	−12A	40W (T_c=25°C)	150	−10	−60	120	−1	−1A			t_{on}<0.9μs, t_f<1.5μs t_{stg}< 3 μs							268	
〃 1329	〃	〃	〃	−80	−60	−12A	40W (T_c=25°C)	150	−10	−80	120	−1	−1A			t_{on}<0.9μs, t_f=1.5μs t_{stg}< 3 μs							268	
〃 1330	日電	RF.AF.SW	〃	−200	−200	−100	200	150	−0.1	−200	200	−10	−10	−10	10	t_{on}=0.16μs t_{off}=1.5μs				120*	3.6		176	2SC3360 とコンプリ
〃 1331	三洋	SW	Si. EP	−60	−50	−150	150	125	−0.1	−40	90~400	−6	−1	−6	1	t_d=40ns, t_{stg}=190ns t_r=120ns, t_f=200ns				100*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 25ps	176	2SC3361 とコンプリ
〃 1332	東芝	PA	Si. E	−160	−160	−1.5A	20W (T_c=25°C)	150	−1	−160	130	−5	−100	−10	100					200*	38	15	381	
〃 1333	〃	RF. PA	Si. T	−200	−200	−15A	150W (T_c=25°C)	150	−10	−200	100	−5	−1A	−5	1A					30*	600	10	125	2SC3370 とコンプリ
〃 1334	〃	RF. AF	Si. E	−30	−25	−800	600	150	−0.1	−30	200	−1	−100	−5	10					120*	19	25	138	2SC3375 とコンプリ
〃 1335	〃	RF. AF. LN	〃	−120	−120	−100	200	125	−0.1	−120	350	−6	−2	−6	2	350	12k	0.012	36	100*	4	18	287	
〃 1336	三菱	RF. AF. PA	Si. EP	−20	−16	−2A	700	150	−0.2	−16	300	−4	−100	−2	10					80*	42	$C_c r_{bb'}$ 250ps	138	
〃 1337	日立	RF	Si. E	−55	−50	−100	300	150	−0.5	−18	250	−12	−2	−12	2					200*	3.3	$C_c r_{bb'}$ 12ps	378	
〃 1338	三洋	AF.PA. SW	Si. EP	−60	−50	−500	200	150	−0.1	−40	100~560	−5	−10	−10	50	t_{on}=70ns, t_f=50ns t_{stg}=400ns				200*	5.6		176	2SC3392 とコンプリ
〃 1339	〃	〃	〃	−60	−50	−500	300	150	−0.1	−40	100~560	−5	−10	−10	50	t_{on}=70ns, t_f=50ns t_{stg}=400ns				200*	5.6		92	2SC3393 とコンプリ
★ 〃 1340	日立	RF	Si. E	−55	−50	−100	400	150	−0.5	−18	250	−12	−2	−12	2					200*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 12ps	379	
〃 1341	三洋	SW	Si. EP	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	200	−5	−5	−10	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=47±15kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				200*	5.3		176	2SC3395 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μS)	f_{ab} / f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1342	三洋	SW	Si.EP	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	200	−5	−5	−10	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=22±7kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				200*	5.3		176	2SC3396とコンプリ
〃 1343	〃	〃	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	200	−5	−5	−10	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=46±14kΩ, R_B/R_{BE}=2.0±0.2)				200*	5.3		176	2SC3397とコンプリ
〃 1344	〃	〃	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	200	−5	−5	−10	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10±3kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				200*	5.3		176	2SC3398とコンプリ
〃 1345	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	200	−5	−5	−10	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=47±15kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				200*	5.5		92	2SC3399とコンプリ
〃 1346	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	200	−5	−5	−10	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=22±7kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				200*	5.5		92	2SC3400とコンプリ
〃 1347	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	200	−5	−5	−10	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=46±14kΩ, R_B/R_{BE}=2.0±0.2)				200*	5.5		92	2SC3401とコンプリ
〃 1348	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	200	−5	−5	−10	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10±3kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				200*	5.5		92	2SC3402とコンプリ
〃 1349	東芝	RF.AF.LN	Si.E	−80	−80	−100	400	125	−0.1	−80	400	−6	−2	−10	10	NF=0.2dB (−6V, −0.1mA, 1kHz)				170*	3.6	20	386	
〃 1350	日立	RF	〃	−40	−30	−100	300	150	−0.5	−18	220	−12	−2	−12	2					200*	3.8	$C_c r_{bb'}$ 15ps	378	
★ 〃 1351	〃	〃	〃	−40	−30	−100	400	150	−0.5	−18	200	−12	−2	−12	2					200*	3.8	$C_c r_{bb'}$ 15ps	379	
〃 1352	三洋	RF.PA	Si.EP	−200	−200	−100	1.2W	150	−0.1	−150	40~320	−40	−10	−30	10					70*	2.6	$C_c r_{bb'}$ 10ps	296	2SC3416とコンプリ
〃 1353	〃	〃	〃	−300	−300	−100	1.2W	150	−0.1	−200	40~320	−40	−10	−30	10					70*	3.1	$C_c r_{bb'}$ 18ps	296	2SC3417とコンプリ
〃 1354	〃	RF	〃	−400	−400	−100	1.2W	150	−0.1	−150	100	−10	−10	−30	10					70*	4.2	$C_c r_{bb'}$ 20ps	296	
〃 1355	サンケン	PA	〃	−70	−50	−4A	30W (T_c=25°C)	150	−100	−70	100	−4	−1A	−12	1A					15*	100	15	298	
〃 1356	東芝	RF	〃	−40	−40	−800	5W (T_c=25°C)	150	−0.1	−40	120	−2	−50	−2	50					100*	20	25	384	2SC3419とコンプリ
〃 1357	〃	〃	〃	−35	−20	−5A	10W (T_c=25°C)	150	−0.1	−35	200	−2	−500	−2	500					170*	62	10	384	2SC3420とコンプリ
〃 1358	〃	〃	〃	−120	−120	−1A	10W (T_c=25°C)	150	−0.1	−120	150	−5	−500	−5	500					120*	30	3	384	2SC3421とコンプリ
〃 1359	〃	〃	〃	−40	−40	−3A	10W (T_c=25°C)	150	−0.1	−40	150	−2	−500	−2	500					100*	35	10	384	2SC3422とコンプリ
〃 1360	〃	〃	〃	−150	−150	−50	5W (T_c=25°C)	150	−0.1	−150	150	−5	−10	−5	10					200*	2.5	50	384	2SC3423とコンプリ
〃 1361	〃	〃	Si.T	−250	−250	−50	1.5W	150	−0.1	−200	80	−20	−25	−10	10					100*	2.5	25	384	
〃 1362	〃	〃	Si.E	−15	−15	−800	200	150	−0.1	−15	300	−1	−100	−5	10					120*	13	20	176	
〃 1363	三菱	RF.AF.PA	Si.EP	−20	−16	−2A	500	150	−0.2	−16	150~800	−4	−100							80*	42	$C_c r_{bb'}$ 250ps	336	2SC3443とコンプリ
〃 1364	〃	〃	〃	−60	−60	−1A	500	150	−0.2	−50	55~300	−4	−100							120*	22	$C_c r_{bb'}$ 65ps	336	2SC3444とコンプリ
〃 1365	〃	〃	〃	−25	−20	−700	150	125	−1	−25	150~800	−4	−100							180*	15	$C_c r_{bb'}$ 100ps	176	2SC3440とコンプリ
〃 1366	〃	〃	〃	−55	−50	−400	150	125	−1	−25	90~500	−4	−100							150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	176	2SC3441とコンプリ
〃 1367	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	125	−0.5	−50	300	−6	−1	−6	1					100*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 300ps	175	
〃 1368	〃	〃	〃	−100	−100	−500	500	150	−0.5	−50	55~300	−10	−10							130*	11	$C_c r_{bb'}$ 30ps	336	2SC3438とコンプリ
〃 1369	〃	〃	〃	−30	−20	−1.5A	500	150	−0.1	−20	400~1200	−6	−500							90*	37	$C_c r_{bb'}$ 300ps	336	2SC3439とコンプリ
〃 1370	三洋	PA	〃	−200	−200	−100	1W	150	−0.1	−150	40~320	−10	−10	−30	10					150*	2.6	$C_c r_{bb'}$ 10ps	294	2SC3467とコンプリ
〃 1371	〃	〃	〃	−300	−300	−100	1W	150	−0.1	−200	40~320	−10	−10	−30	10					150*	3.1	$C_c r_{bb'}$ 18ps	294	2SC3468とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1372	三洋	PA	Si.EP	−400	−400	−100	1 W	150	−0.1	−150	100	−10	−10	−30	10					150*	4.2	$C_c r_{bb'}$ 20ps	294	
★ 〃 1373	日立	RF	Si.E	−60	−50	−200	400	150	−0.1	−50	300	−6	−1	−6	10					250*	4.5	1 k*	138B	
〃 1374	〃	〃	〃	−55	−55	−100	300	150	−0.1	−18	320	−12	−2	−12	2					250*	2.5	15*	378	
〃 1375	松下	〃	Si.EP	−250	−200	−70	10W (T_c=25°C)	150	−1	−10	100	−10	−5	−10	10					80*	5		361	
〃 1376	日電	AF.PA	Si.E	−200	−180	−100	750	150	−0.1	−200	300	−10	−10	−10	10	t_{on}=0.16μs, t_{off}=1.5μs				120*	3.5		138	2SC3478 とコンプリ ○
★ 〃 1377	東芝	RF.AF	〃	−50	−50	−100	300	125	−0.1	−50	250	−6	−2	−6	2					150*	4	50	138	2SC3487 とコンプリ
〃 1378	〃	〃	〃	−35	−30	−500	300	150	−0.1	−35	120	−1	−100	−6	20					200*	13	$C_c r_{bb'}$ 100ps	287	
★ 〃 1379	日立	SW	Si.P	−600	−600	−800	10W (T_c=25°C)	150	−50	−500	18	−5	−400			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<16 μs							245	
〃 1380	三洋	PA	Si.EP	−200	−200	−100	1.2W	150	−0.1	−150	100	−10	−10	−30	10					150*	2.6		296	2SC3502 とコンプリ
〃 1381	〃	〃	〃	−300	−300	−100	1.2W	150	−0.1	−200	100	−10	−10	−30	10					150*	3.1		296	2SC3503 とコンプリ
〃 1382	東芝	SW	Si.E	−50	−50	−2A	900	150	−0.1	−50	250	−2	−500			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μS t_{stg}< 3 μs							241	
〃 1383	日電	PA	Si.E	−180	−180	−100	10W (T_c=25°C)	150	−1	−180	200	−5	−10	−10	20					180*	4.5	26*	268	2SC3514 とコンプリ
〃 1384	東芝	RF	Si.T	−300	−300	−100	1 W	150	−0.1	−300	90	−10	−20	−10	20					70*	6	15	336	
〃 1385	日電	PA.SW	Si.E	−60	−60	−5A	10W (T_c=25°C)	150	−10	−50	200	−1	−2A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							186	
〃 1386	サンケン	PA	Si.EP	−160	−160	−15A	130W (T_c=25°C)	150	−100	−160	80	−4	−5A	−12	2 A					40*	500	8	324	2SC3519 とコンプリ ○
〃 1387	東芝	SW	Si.E	−60	−50	−5A	25W (T_c=25°C)	150	−1	−50	250	−1	−1A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							381	
〃 1388	〃	〃	〃	−100	−80	−5A	25W (T_c=25°C)	150	−1	−100	150	−1	−1A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.2μs t_{stg}< 2 μs							381	
〃 1389	〃	PA	Si.T	−160	−160	−12A	120W (T_c=25°C)	150	−10	−160	100	−5	−1A	−5	1 A					30*	500	10	125	2SC3546 とコンプリ
〃 1390	日立	RF	Si.E	−35	−35	−500	300	150	−0.5	−20	130	−3	−10	−3	10					120*	9	12*	378	
〃 1391	三洋	LN	Si.EP	−60	−50	−200	400	150	−0.1	−40	280	−6	−1		V_{NO}=−13〜35mV (V_{CC}=30V, I_C= 1 mA, R_G=56kΩ, G_v=77dB)								138	2SC3382 とコンプリ
〃 1392	〃	AF	〃	−60	−50	−200	500	150	−0.1	−40	280	−6	−1										138	2SC3383 とコンプリ
〃 1393	日電	PA	Si.E	−120	−120	−1.5A	20W (T_c=25°C)	150	−1	−120	150	−5	−300	−5	200					180*	29		96	2SC3564 とコンプリ
〃 1394	〃	SW	〃	−80	−60	−5A	25W (T_c=25°C)	150	−10	−60	40〜200	−5	−3A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							96	2SC3566 とコンプリ
〃 1395	〃	〃	〃	−100	−100	−2A	15W (T_c=25°C)	150	−10	−100	40〜200	−5	−1A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							96	2SC3567 とコンプリ
〃 1396	〃	〃	〃	−100	−100	−10A	30W (T_c=25°C)	150	−10	−100	40〜200	−5	−3A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							96	2SC3568 とコンプリ
〃 1397	〃	〃	Si.T	−400	−400	−2A	15W (T_c=25°C)	150	−10	−400	80	−5	−100			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							96	2SC3569 とコンプリ
〃 1398	三菱	RF.AF	Si.EP	−25	−20	−700	900	150	−0.2	−25	300	−4	−100	−6	10					180*	16	$C_c r_{bb'}$ 180ps	66	
〃 1399	〃	〃	〃	−65	−60	−400	900	150	−0.2	−55	250	−4	−100	−6	10					130*	10	$C_c r_{bb'}$ 50ps	6	2SC3581 とコンプリ
〃 1400	日電	SW	Si.T	−400	−400	−500	10W (T_c=25°C)	150	−100	−400	30〜200	−5	−50			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 5 μs							186	2SC3588 とコンプリ
〃 1401	〃	〃	Si.E	−60	−60	−5A	10W (T_c=25°C)	150	−10	−50	250	−1	−2A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							185	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1402	三洋	RF	Si.EP	−80	−60	−300	1.2W	150	−0.1	−60	90	−5	−50	−10	100					700*	3	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	296	2SC3596 とコンプリ
〃 1403	〃	〃	〃	−80	−60	−500	1.2W	150	−0.1	−60	90	−10	−50	−10	100					800*	5.2	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	296	2SC3597 とコンプリ
〃 1404	〃	〃	〃	−120	−120	−200	1.2W	150	−0.1	−80	90	−10	−10	−10	10					500*	2.7	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	296	2SC3598 とコンプリ
〃 1405	〃	〃	〃	−120	−120	−300	1.2W	150	−0.1	−80	90	−10	−50	−10	50					500*	4.3	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	296	2SC3599 とコンプリ
〃 1406	〃	〃	〃	−200	−200	−100	1.2W	150	−0.1	−150	90	−10	−10	−30	30					400*	2.3	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	296	2SC3600 とコンプリ
〃 1407	〃	〃	〃	−200	−200	−150	1.2W	150	−0.1	−150	90	−10	−10	−30	50					400*	3	5*	296	2SC3601 とコンプリ
〃 1408	東芝	〃	Si.E	−150	−150	−1.5A	1.5W	150	−1	−150	120	−5	−200	−5	200					140*	25	50	384	2SC3621 とコンプリ
〃 1409	日電	AF.RF.SW	〃	−25	−25	−150	250	150	−0.1	−25	1000	−5	−1	−5	10	t_{on}=0.12μs, t_{off}=0.75μs t_{stg}=0.58μs				200*	4.6		138	2SC3632 とコンプリ
〃 1410	〃	〃	〃	−25	−25	−150	250	150	−0.1	−25	1000	−5	−1	−5	10	t_{on}=0.12μs, t_{off}=0.75μs t_{stg}=0.58μs				200*	4.6		42	2SC3623 とコンプリ
〃 1411	〃	〃	〃	−25	−25	−150	200	150	−0.1	−25	1000	−5	−1	−5	10	t_{on}=0.12μs, t_{off}=0.75μs t_{stg}=0.58μs				200*	4.6		176	2SC3624 とコンプリ
〃 1412	〃	SW	Si.T	−400	−400	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−400	60	−5	−100	−10	100					40*	30		186	2SC3631 とコンプリ
〃 1413	〃	〃	〃	−600	−600	−1A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−600	58	−5	−100	−10	50					28*	42		186	2SC3632 とコンプリ
★ 〃 1414												5												
〃 1415	三洋	RF	Si.EP	−180	−160	−140	500	150	−0.1	−80	200	−5	−10	−10	10					150*	4	$C_c r_{bb'}$ 10ps	336	2SC3645 とコンプリ
〃 1416	〃	〃	〃	−100	−100	−1A	500	150	−1	−80	150	−10	−100	−10	100					120*	15	$C_c r_{bb'}$ 30ps	336	
〃 1417	〃	〃	〃	−100	−100	−2A	500	150	−1	−80	150	−10	−100	−10	100					120*	25	$C_c r_{bb'}$ 30ps	336	
〃 1418	〃	〃	〃	−180	−160	−700	500	150	−0.1	−120	200	−10	−100	−10	50					120*	11	$C_c r_{bb'}$ 30ps	336	2SC3648 とコンプリ
〃 1419																								
〃 1420	三洋	SW	Si.EP	−50	−50	−100	400	150	−0.1	−40	>50	−5	−5	−10	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=47±15kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				200*	5.5		138	2SC3653 とコンプリ
〃 1421	〃	〃	〃	−50	−50	−100	400	150	−0.1	−40	>50	−5	−5	−10	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=22±7kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				200*	5.5		138	2SC3654 とコンプリ
〃 1422	〃	〃	〃	−50	−50	−100	400	150	−0.1	−40	>50	−5	−5	−10	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=46±14kΩ, R_B/R_{BE}=2.0±0.2)				200*	5.5		138	2SC3655 とコンプリ
〃 1423	〃	〃	〃	−50	−50	−100	400	150	−0.1	−40	>50	−5	−5	−10	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10±3kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				200*	5.5		138	2SC3656 とコンプリ
〃 1424	日電	RF	Si.E	−20	−12	−50	250	150	−0.1	−10	90	−10	−15	−10	15	NF=3dB (−10V, −3mA, 1GHz)				4000*	C_{re} 1.5		176	2SC2351 とコンプリ
〃 1425	東芝	〃	〃	−120	−120	−800	1W	150	−0.1	−120	140	−5	−100	−5	100					120*	27	3*	387	
〃 1426	〃	〃	〃	−35	−30	−800	1W	150	−0.1	−35	200	−1	−100	−5	10					120*	19	25	387	
〃 1427	〃	〃	〃	−30	−30	−1.5A	1W	150	−0.1	−30	200	−2	−500	−2	500					120*	20	5*	387	
〃 1428	〃	〃	〃	−50	−50	−2A	1W	150	−1	−50	150	−2	−500	−2	500					100*	40	5*	387	
〃 1429	〃	RF.SW	〃	−80	−80	−2A	1W	150	−1	−80	150	−2	−500	−2	500					80*	45	5*	387	
〃 1430	〃	RF	〃	−20	−10	−2A	1W	150	−0.1	−20	240	−1	−500	−1	500					140*	50	11	387	
〃 1431	〃	〃	〃	−35	−20	−5A	1W	150	−0.1	−35	150	−2	−500	−2	500					170*	62	10*	387	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1432	東芝	RF	Si. E	−300	−300	−100	1 W	150	−0.1	−300	90	−10	−20	−10	20					70 *	6	15	387	
〃 1433	三洋	〃	Si. EP	−70	−60	−50	900	150	−0.1	−40	200	−10	−10	−10	10					500 *	1.7	$C_c r_{bb'}$ 8 pS	294	
〃 1434	〃	〃	〃	−60	−50	−100	200	125	−0.1	−40	800	−5	−10	−10	10					100 *	4.8	$C_c r_{bb'}$ 75ps	176	
〃 1435	〃	〃	〃	−30	−25	−300	600	150	−0.1	−20	800	−5	−10	−10	10					100 *	12	$C_c r_{bb'}$ 75ps	138	
〃 1436	〃	〃	〃	−60	−50	−200	600	150	−0.1	−40	800	−5	−10	−10	10					100 *	7.5	$C_c r_{bb'}$ 55ps	138	
〃 1437	〃	〃	〃	−120	−100	−50	500	150	−0.1	−80	700	−5	−10	−10	10					85 *	4	$C_c r_{bb'}$ 51ps	138	2SC3495とコンプリ
〃 1438	〃	〃	〃	−30	−25	−1.2A	1 W	150	−0.1	−20	750	−5	−500	−10	10					100 *	12	$C_c r_{bb'}$ 195ps	294	
★ 〃 1439	〃																							
〃 1440	日電	SW	Si. E	−100	−60	−3A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−100	200	−2	−600			t_{on}<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							96	
〃 1441	〃	〃	〃	−100	−60	−5A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−60	200	−2	−1A	−10	500	t_{on}<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs				80 *	130		96	
〃 1442	〃	〃	〃	−100	−60	−7A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−60	200	−2	−1.5A	−10	1 A	〃				40 *	180		96	
〃 1443	〃	〃	〃	−100	−60	−10A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−60	200	−2	−2A	−10	1 A	〃				80 *	230		96	
〃 1444	〃	〃	〃	−100	−60	−15A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−60	200	−2	−3A	−10	1.5A	〃				80 *	300		96	
〃 1445																								
〃 1446																								
〃 1447																								
〃 1448																								
〃 1449																								
〃 1450	三洋	RF	Si. EP	−100	−80	−500	600	150	−0.1	−60	150	−10	−10	−10	10					120 *	7	$C_c r_{bb'}$ 45pS	138	2SC3708とコンプリ
〃 1451	東芝	SW	Si. E	−60	−50	−12A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−60	120	−1	−1A			t_{on}<0.9μs, t_f<1.5μs t_{stg}< 3 μs							381	
〃 1452	〃	〃	〃	−80	−80	−12A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−80	120	−1	−1A			〃							381	
★ 〃 1453	〃	RF	Si. EP	−50	−50	−100	200	125	−0.1	−50	250	−6	−2	−6	2					200 *	2.4	30	287	
〃 1454																								
〃 1455																								
〃 1456																								
〃 1457																								
〃 1458	日電	RF. SW	Si. E	−40	−40	−200	250	150	−0.1	−30	180	−1	−10	−20	10	t_{on}<70ns, t_{off}<300ns t_{stg}<225ns				510 *	2.5		42	2SC3731とコンプリ
〃 1459	〃	SW	〃	−15	−15	−50	250	150	−0.1	−8	80	−1	−10	−10	10	t_{on}<20ns, t_{off}<40ns t_{stg}<40ns				1800*	2		42	2SC3732とコンプリ
〃 1460	〃	〃	〃	−60	−45	−1A	1 W	150	−0.5	−45	60~200	−10	−50	−10	100	t_{on}<40ns, t_{off}<100ns t_{stg}<70ns				400 *	11		278	2SC3733とコンプリ
〃 1461	〃	RF. SW	〃	−40	−40	−200	200	150	−0.1	−30	180	−1	−10	−20	10	t_{on}<70ns, t_{off}<300ns t_{stg}<225ns				510 *	2.5		176	2SC3734とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1462	日電	SW	Si. E	−15	−15	−50	200	150	−0.1	−8	80	−1	−10	−10	10	t_{on}<20ns, t_{stg}<40ns			t_{off}<40ns	1800*	2		176	2SC3735 とコンプリ
〃 1463	〃	〃	〃	−60	−45	−1A	1 W (セラミック基板使用)		−0.5	−45	60~200	−10	−50	−10	100	t_{on}<40ns, t_{stg}<70ns			t_{off}<100ns	400*	11		336	2SC3736 とコンプリ
〃 1464	〃	RF. SW	〃	−60	−40	−500	200	150	−0.1	−40	140	−2	−150	−10	20	t_{on}<35ns, t_{stg}<225ns			t_{off}<255ns	400*	5		176	2SC3739 とコンプリ
〃 1465	〃	SW	〃	−30	−25	−1A	400 (セラミック基板使用)	150	−0.1	−25	200	−1	−100			t_{on}< 1 μs, t_{stg}< 2 μs			t_{off}< 2 μs				138	2SC3740 とコンプリ
〃 1466	〃	〃	〃	−30	−25	−1A	350 (セラミック基板使用)	150	−0.1	−25	200	−1	−100			t_{on}< 1 μs, t_{stg}< 2 μs			t_{off}< 2 μs				42	2SC3741 とコンプリ
〃 1467	〃	〃	〃	−30	−25	−1A	200 (セラミック基板使用)	150	−0.1	−25	200	−1	−100			〃							176	2SC3742 とコンプリ
〃 1468	日立	RF	〃	−180	−180	−100	150	150	−10	−180	100~320	−12	−2	−12	10					200*	3.5		176	
〃 1469	三洋	SW	Si. EP	−80	−60	−5A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−60	150	−2	−1A			t_{on}<0.1μs, t_{stg}<0.7μs			t_f<0.2μs				388	
〃 1470	〃	〃	〃	−80	−60	−7A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−60	150	−2	−1A			〃							388	
〃 1471	〃	〃	〃	−80	−60	−12A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−60	150	−2	−1A			〃							388	
★ 〃 1472																								
★ 〃 1473																								
〃 1474	三洋	RF	Si. EP	−80	−60	−600	1.75W	150	−0.1	−60	100	−10	−50	−10	100					800*	5.3	$C_c r_{bb'}$ 5ps	268	2SC3780 とコンプリ
〃 1475	〃	〃	〃	−120	−120	−400	1.75W	150	−0.1	−80	100	−10	−50	−10	50					500*	4.4	〃	268	2SC3781 とコンプリ
〃 1476	〃	〃	〃	−200	−200	−200	1.75W	150	−0.1	−150	100	−10	−10	−30	50					400*	3.1	〃	268	2SC3782 とコンプリ
〃 1477	〃	SW	〃	−180	−160	−140	10W (Tc=25°C)	150	−0.1	−120	200	−5	−10	−10	10	t_{on}<0.1μs, t_{stg}<1.5μs			t_f<0.1μs	150*	4		389	2SC3787 とコンプリ
〃 1478	〃	RF	〃	−200	−200	−100	5 W (Tc=25°C)	150	−0.1	−150	100	−30	−10	−30	10					150*	2.6	$C_c r_{bb'}$ 18ps	389	2SC3788 とコンプリ
〃 1479	〃	〃	〃	−300	−300	−100	7 W (Tc=25°C)	150	−0.1	−200	100	−30	−10	−30	10					70*	3.1	〃	389	2SC3789 とコンプリ
〃 1480	〃	〃	〃	−300	−300	−100	7 W (Tc=25°C)	150	−0.1	−200	100	−10	−10	−30	10					150*	3.1	〃	389	2SC3790 とコンプリ
〃 1481	〃	SW	〃	−60	−50	−150	250	150	−0.1	−40	180	−6	−1	−6	1	t_r<360ns, t_{stg}<570ns			t_f<600ns	100*	4		92	2SC2960 とコンプリ
〃 1482	ローム	RF. LN	〃	−150	−150	−50	800	135	−0.5	−125	220	−6	−2			NF=0.2dB (−6V, −0.1mA, 100Hz)							294	2SC3800 とコンプリ
〃 1483	東芝	RF	Si. E	−60	−45	−200	500	150	−0.1	−30	65	−1	−10	−10	10					200*	4	40*	336	
〃 1484	日立	RF. PA	〃	−90	−90	−100	150	150	−0.1	−70	500	−12	−2	−6	10					130*	3.2	30	176	
〃 1485	〃	RF	〃	−200	−200	−100	200	150	−10	−200	175	−12	−2	−12	10					160*	3	12*	138	
〃 1486	日電	SW	Si. T	−600	−600	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−600	60	−5	−100			t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 5 μs			t_f<0.5μs				225	
〃 1487	松下	PA	Si. EP	−85	−85	−50	1 W	150	−100	−85	150	−5	−10	−5	10					400*	2.7	400	294	
〃 1488	サンケン	〃	〃	−60	−60	−4A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−60	100	−4	−1A	−12	200					15*	90	7	400	2SC3851 とコンプリ
〃 1489	〃	〃	〃	−80	−80	−6A	60W (Tc=25°C)	150	−100	−80	>50	−4	−2A	−12	500					20*			324	2SC3853 とコンプリ
〃 1490	〃	〃	〃	−120	−120	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−120	>50	−4	−3A	−12	500					20*			324	2SC3854 とコンプリ
〃 1491	〃	〃	〃	−140	−140	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−140	>50	−4	−3A	−12	500					20*			324	2SC3855 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SA1492	サンケン	PA	Si.EP	−180	−180	−15A	130W (Tc=25°C)	150	−100	−180	>50	−4	−3A	−12	500					20 *			324	2SC3856 とコンプリ
〃 1493	〃	〃	〃	−200	−200	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−100	−200	>30	−4	−5A	−12	500					20 *			256	2SC3857 とコンプリ
〃 1494	〃	〃	〃	−200	−200	−17A	200W (Tc=25°C)	150	−100	−200	>30	−4	−8A	−12	500					20 *			256	2SC3858 とコンプリ
〃 1495	松下	SW	〃	−400	−400	−600	15W (Tc=25°C)	150	−100	−400	80	−5	−100			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3.5μs							392	
〃 1496	三洋	〃	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	300	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10k±3kΩ)						200 *	5.3		176	2SC3859 とコンプリ
〃 1497	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	300	−5	−10	〃						200 *	5.5		92	2SC3860 とコンプリ
〃 1498	松下	〃	〃	−400	−400	−600	25W (Tc=25°C)	150	−100	−400	80	−5	−100			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3.5μs							363	
〃 1499	〃	〃	〃	−400	−400	−600	25W (Tc=25°C)	150	−100	−400	80	−5	−100			〃							364	
〃 1500	〃	〃	〃	−400	−400	−5A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−400	15	−5	−2A										268	
〃 1501	〃	〃	〃	−400	−400	−5A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−400	15	−5	−2A										364	
〃 1502	三洋	〃	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	250	−5	−1	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=0.22±0.022)						200 *	5.3		176	2SC3863 とコンプリ
〃 1503	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	250	−5	−10	〃						200 *	5.5		92	2SC3864 とコンプリ
〃 1504	韓国電子	RF.AF	〃	−50	−50	−150	150	125	−0.1	−50	185	−6	−2	−10	1	NF=1dB (−10V, −0.1mA, 1kHz)				130 *	4	30	176C	
〃 1505	〃	〃	〃	−35	−30	−500	150	125	−0.1	−35	150	−1	−100	−6	20					200 *	7	$C_c r_{bb'}$ 70pS	176C	
〃 1506	〃	RF.AF.LN	〃	−120	−120	−100	150	125	−0.1	−120	400	−6	−2	−6	1	NF=0.2dB (−6V, −0.1mA, 1kHz)				100 *	4	11	176C	
〃 1507	三洋	SW	〃	−180	−160	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−120	250	−5	−100	10	−50	t_{on}<0.04μs, t_f<0.04μs t_{stg}<0.7μs				120 *	22		389	2SC3802 とコンプリ
〃 1508	〃	〃	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	250	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=47k±14kΩ)						200 *	5.5		176	2SC3898 とコンプリ
〃 1509	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	250	−5	−100	〃						200 *	5.5		92	2SC3899 とコンプリ
〃 1510	〃	〃	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	250	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ)						200 *	5.5		176	2SC3900 とコンプリ
〃 1511	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	200	−5	−10	〃									92	2SC3901 とコンプリ
〃 1512	松下	RF.AF	〃	−25	−25	−500	250	125	−0.1	−25	150	−2	−500										376	
〃 1513	日電	SW	Si.E	−100	−60	−15A	60W (Tc=25°C)	150	−10	−60	200	−2	−3A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							404	
〃 1514	ローム	RF.AF	Si.EP	−120	−120	−50	200	125	−0.5	−100	390	−6	−2	−6	1		14.8k	0.87	15.8	140 *	4	$C_c r_{bb'}$ 140ps	335	
〃 1515	〃	〃	〃	−40	−32	−1A	300	125	−0.5	−20	180	−3	−100	−5	50					150 *	20	$C_c r_{bb'}$ 80ps	138	2SC3377 とコンプリ
〃 1516	東芝	PA	Si.T	−180	−180	−12A	130W (Tc=25°C)	150	−5	−180	100	−5	−1A	−5	1A					25 *	470	10	203	2SC3907 とコンプリ
〃 1517	韓国電子	RF.LN	Si.EP	−120	−120	−100	150	125	−0.1	−120	415	−6	−2	−6	1	350	12k	1.2	13	100 *	4	13	176C	
〃 1518	三洋	SW	〃	−50	−50	−500	200	150	−0.1	−40	200	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10k±3kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						200 *	5.5		176	2SC3912 とコンプリ
〃 1519	〃	〃	〃	−50	−50	−500	200	150	−0.1	−40	200	−5	−20	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						200 *	5.5		176	2SC3913 とコンプリ
〃 1520	〃	〃	〃	−50	−50	−500	200	150	−0.1	−40	200	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=0.22±0.022)						200 *	5.5		176	2SC3914 とコンプリ
〃 1521	〃	〃	〃	−50	−50	−500	200	150	−0.1	−40	200	−5	−50	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						200 *	5.5		176	2SC3915 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
2SA1522	三洋	SW	Si. EP	−50	−50	−500	300	150	−0.1	−40	200	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10k±3kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						200*	5.5		92	2SC3916とコンプリ	
〃 1523	〃	〃	〃	−50	−50	−500	300	150	−0.1	−40	200	−5	−20	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						200*	5.5		92	2SC3917とコンプリ	
〃 1524	〃	〃	〃	−50	−50	−500	300	150	−0.1	−40	200	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=0.22±0.022)						200*	5.5		92	2SC3918とコンプリ	
〃 1525	〃	〃	〃	−50	−50	−500	300	150	−0.1	−40	200	−5	−50	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						200*	5.5		92	2SC3919とコンプリ	
〃 1526	〃	〃	〃	−50	−50	−500	600	150	−0.1	−40	200	−5	−50	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10k±3kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						200*	5.5		138	2SC3920とコンプリ	
〃 1527	〃	〃	〃	−50	−50	−500	600	150	−0.1	−40	200	−5	−20	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)									138	2SC3921とコンプリ	
〃 1528	〃	〃	〃	−50	−50	−500	600	150	−0.1	−40	200	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=0.22±0.022)						200*	5.5		138	2SC3922とコンプリ	
〃 1529	〃	〃	〃	−50	−50	−500	600	150	−0.1	−40	200	−5	−50	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						200*	5.5		138	2SC3923とコンプリ	
〃 1530	三菱	RF. AF	Si. E	−50	−50	−100	150	125	−0.5	−50	300	−6	−1	−6	10					200*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 300ps	176		
〃 1531	松下	RF	Si. EP	−35	−35	−50	150	150	−0.1	−10	350	−5	−2	−10	10					200*	6	200	412	2SC3929とコンプリ	○
〃 1532	〃	〃	〃	−30	−20	−30	150	150	−0.1	−10	50~220	−10	−1	−10	1					300*	1.2	650	412	2SC3930とコンプリ	○
〃 1533	〃	〃	〃	−80	−80	−500	1 W	150	−0.1	−20	180	−10	−150	−10	50					120*	11	20	413	2SC3939とコンプリ	
〃 1534	〃	〃	〃	−30	−25	−1A	1 W	150	−0.1	−20	180	−10	−500	−10	50					200*	20	15	413	2SC3940とコンプリ	
〃 1535	〃	PA	〃	−150	−150	−1A	40W (T_c=25°C)	150	−100	−100	160	−10	−150	−10	50					200*	30	3	364	2SC3944とコンプリ	○
〃 1536	三洋	RF	〃	−80	−70	−200	8 W (T_c=25°C)	150	−0.1	−70	120	−10	−50	−10	100					600*	3	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	389	2SC3951とコンプリ	
〃 1537	〃	〃	〃	−80	−70	−500	10W (T_c=25°C)	150	−0.1	−70	120	−10	−50	−10	100					700*	5.4	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	389	2SC3952とコンプリ	
〃 1538	〃	〃	〃	−120	−120	−200	8 W (T_c=25°C)	150	−0.1	−120	120	−10	−10	−10	50					400*	2.8	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	389	2SC3953とコンプリ	
〃 1539	〃	〃	〃	−120	−120	−300	8 W (T_c=25°C)	150	−0.1	−120	120	−10	−50	−10	50					400*	4.4	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	389	2SC3954とコンプリ	
〃 1540	〃	〃	〃	−200	−200	−100	7 W (T_c=25°C)	150	−0.1	−200	120	−10	−10	−30	30					300*	2.4	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	389	2SC3955とコンプリ	
〃 1541	〃	〃	〃	−200	−200	−200	7 W (T_c=25°C)	150	−0.1	−200	120	−10	−10	−30	50					300*	3.2	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	389	2SC3956とコンプリ	
〃 1542	ローム	RF. AF	〃	−60	−50	−150	300	150	−0.5	−30	180	−6	−1	−6	1		8.8k	0.63	17.7	140*	4	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138	2SC3983とコンプリ	
〃 1543	〃	〃	〃	−60	−50	−150	300	150	−0.5	−30	180	−6	−1	−6	1		8.8k	0.63	17.7	140*	4	$C_c r_{bb'}$ 150ps	235		
〃 1544	日電	RF	Si. E	−250	−250	−100	750	150	−0.1	−200	150	−10	−10	−30	30					300*	3.3	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	138	2SC3999とコンプリ	
〃 1545	〃	〃	〃	−250	−250	−100	1 W	150	−0.1	−200	150	−10	−10	−30	30					300*	3.3	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	278	2SC4000とコンプリ	
〃 1546	〃	〃	〃	−250	−250	−100	1.3W	150	−0.1	−200	150	−10	−10	−30	30					300*	3.3	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	225	2SC4001とコンプリ	
〃 1547	ローム	RF. AF	Si. EP	−50	−40	−100	300	125	−0.5	−30	180	−6	−1	−6	1		8.75k	0.625	17.7	150*	4	$C_c r_{bb'}$ 150ps	415		
〃 1548	〃	〃	〃	−40	−30	−500	300	125	−1	−20	180	−3	−100	−6	1		4.5k	0.65	13	200*	7.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	415		
〃 1549	〃	RF.Conv.Mix Osc. PA	〃	−40	−32	−300	300	125	−1	−24	10000	−5	−100	−5	10					200*	5.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	415		
〃 1550	松下	SW	Si. TP	−400	−400	−500	15W (T_c=25°C)	150	−100	−400	45	−5	−100			t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<5 μs							392		
〃 1551																									

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1552	三洋	RF.SW	Si.EP	−180	−160	−1.5A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−120	250	−5	−100	−10	50					120*	22	$C_c r_{bb'}$ 30ps	411	2SC4027とコンプリ
〃 1553	東芝	PA	Si.T	−230	−230	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−5	−230	100	−5	−1A	−5	1A					25*	470	10	152	
〃 1554	ローム	RF.AF.PA	Si.EP	−80	−80R	−50	150	125	−1	−50	180	−3	−10	−5	10					180*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	415	
〃 1555	〃	〃	〃	−40	−32S	−300	300	125	−1	−24	10000	−5	−100	−5	10					200*	5.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	415	ダーリントン
〃 1556	〃	〃	〃	−130	−130R	−30	150	125	−1	−80	120	−3	−5	−5	2					50*	8	$C_c r_{bb'}$ 200ps	415	
〃 1557	〃	〃	〃	−180	−180R	−30	150	125	−1	−120	120	−3	−5	−5	2					50*	8	$C_c r_{bb'}$ 200ps	415	
〃 1558	〃	〃	〃	−210	−210R	−30	150	125	−1	−150	120	−3	−5	−5	2					50*	8	$C_c r_{bb'}$ 200ps	415	
〃 1559	〃	〃	〃	−40	−30	−500	300	125	−1	−20	180	−3	−100	−5	20					200*	8	$C_c r_{bb'}$ 150ps	415	
〃 1560	〃	RF.AF	〃	−40	−32	−1A	300	125	−0.5	−20	180	−3	−100	−5	50					150*	20	$C_c r_{bb'}$ 80ps	415	
〃 1561	〃	〃	〃	−50	−40	−100	300	125	−0.5	−30	180	−6	−1	−6	1		8.8k	0.63	17.7	140*	4	$C_c r_{bb'}$ 150ps	415	
〃 1562	三洋	RF	〃	−30	−25	−1.2A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−20	800	−5	−100	−10	50					130*	40	$C_c r_{bb'}$ 190ps	411	
〃 1563	〃	SW	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	130	−5	−5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10kΩ, R_{BE}=47kΩ)						200*	5.5		176	2SC4047とコンプリ
〃 1564	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	130	−5	−5	〃						200*	5.5		92	2SC4048とコンプリ
〃 1565	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	130	−5	−5	〃						200*	5.5		92C	2SC4049とコンプリ
〃 1566	日立	RF	Si.E	−120	−120	−100	150	150	−0.1	−70	400	−12	−2	−6	10					130*	3.2	30	176	2SC4050とコンプリ
〃 1567	サンケン	PA	Si.EP	−50	−50	−12A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−50	100	−1	−6A	−12	500					40*	330	11	400	
〃 1568	〃	〃	〃	−60	−60	−12A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−60	100	−1	−6A	−12	500					40*	330	11	400	
〃 1569																								
〃 1570																								
〃 1571	三洋	SW	Si.EP	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	200	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_{BE}=47kΩ)						200*	5.5		176	2SC4066とコンプリ
〃 1572	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	200	−5	−10	〃						200*	5.5		92	2SC4067とコンプリ
〃 1573	〃	〃	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	150	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_{BE}=22kΩ)						200*	5.5		176	2SC4069とコンプリ
〃 1574	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	150	−5	−10	〃						200*	5.5		92	2SC4070とコンプリ
〃 1575	〃	RF	〃	−200	−200	−100	500	150	−0.1	−150	100	−10	−10	−30	30					400*	2.3	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	336	
〃 1576	ローム	RF.AF	〃	−50	−40	−100	200	125	−0.5	−30	180	−6	−1	−6	1	8.8k	63	17.7		140*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	412	
〃 1577	〃	〃	〃	−40	−32	−500	200	125	−1	−20	180	−3	−10	−5	20					200*	7	$C_c r_{bb'}$ 150ps	412	
〃 1578	〃	RF.AF.LN	〃	−120	−120	−50	200	125	−0.5	−100	330	−6	−2	−6	2	NF=0.2dB (−6V, −0.1mA, 100Hz)				140*	3.4	$C_c r_{bb'}$ 130ps	412	
〃 1579	〃	RF.AF	〃	−120	−120	−50	200	125	−0.5	−100	300	−6	−2	−6	1	300	14.8k	87	15.8	140*	4	$C_c r_{bb'}$ 130ps	412	
〃 1580	三洋	RF	〃	−70	−60	−50	200	150	−0.1	−40	200	−10	−10	−10	10					700*	1.7	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	176	
〃 1581	〃	SW	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	300	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ)						200*	5.5		176	2SC4112とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1582	三洋	SW	Si.EP	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	300	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ)						200*	5.5		92	2SC4113とコンプリ
〃 1583	松下	〃	Si.TP	−600	−550	−100	1W (Tc=25°C)	150	−100	−600	100	−5	−10			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3.5μs							336	
〃 1584	ローム	〃	〃	−400	−400	−100	900	150	−10	−400	100	−10	−10	−10	10	t_{on}<1μs, t_f<1.5μs t_{stg}<2.5μs				20*	15		294	
〃 1585	〃	AF.SW.PA	Si.EP	−20	−20	−2A	400	150	−0.1	−20	200	−3	−100			〃							406	
〃 1586	東芝	RF.AF	〃	−50	−50	−150	100	125	−0.1	−50	200	−6	−2	−10	1					150*	4	30	412	
〃 1587	〃	RF.AF.LN	〃	−120	−120	−100	100	125	−0.1	−120	350	−6	−2	−6	1	NF=1dB (−6V, −0.1mA, 1kHz)				100*	3	18	412	
〃 1588	〃	RF.AF	〃	−35	−30	−500	100	125	−0.1	−35	200	−1	−100	−6	20					200*	13	20	412	
〃 1589	三洋	SW	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	300	−5	−1	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=22k±7kΩ)						200*	5.5		176	2SC4120とコンプリ
〃 1590	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	300	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=22k±7kΩ)						200*	5.5		92	2SC4121とコンプリ
〃 1591	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	150	−5	−5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_B/R_{BE}=0.1±0.01)						200*	5.5		92	2SC4133とコンプリ
〃 1592	〃	RF	〃	−120	−100	−1A	10W (Tc=25°C)	150	−0.1	−100	200	−5	−100	−10	100					120*	13	$C_c r_{bb'}$ 30ps	411	2SC4134とコンプリ
〃 1593	〃	〃	〃	−120	−100	−2A	15W (Tc=25°C)	150	−0.1	−100	200	−5	−100	−10	100					120*	25	$C_c r_{bb'}$ 30ps	411	2SC4135とコンプリ
〃 1594	ローム	RF.AF	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.5	−50	180	−6	−1	−12	2					140*	4	$C_c r_{bb'}$ 150ps	412	
〃 1595	〃	〃	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.5	−50	180	−6	−1	−12	2					140*	4	$C_c r_{bb'}$ 150ps	176	
〃 1596	〃	AF.SW	〃	−80	−80	−2A	1.2W (Tc=25°C)	150	−1	−80	180	−2	−500			t_{on}<1μs, t_f<1.5μs t_{stg}<2.5μs							294	
〃 1597	三洋	SW	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	150	−5	−5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_B/R_{BE}=0.1±0.01)						200*	5.3		176	2SC4146とコンプリ
〃 1598	新電元	〃	〃	−60	−40	−7A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−60	150	−2	−3.5A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							410	
〃 1599	〃	〃	〃	−60	−40	−10A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−60	150	−2	−5A			〃							410	
〃 1600	〃	〃	〃	−60	−40	−12A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−60	150	−2	−6A			〃							410	
〃 1601	〃	〃	〃	−60	−40	−15A	45W (Tc=25°C)	150	−100	−60	150	−2	−7.5A			〃							410	
〃 1602	三菱	RF.AF	Si.E	−50	−50	−200	150	125	−0.1	−50	300	−6	−1	−6	10					200*	5.5	$C_c r_{bb'}$ 660ps	412	
〃 1603	〃	〃	〃	−50	−50	−100	150	125	−0.5	−50	300	−6	−1	−6	10					200*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 300ps	412	
〃 1604	三洋	Diff	Si.EP	−60	−50	−500	200/unit	150	−0.1	−40	300	−5	−10	−10	50	ΔV_{BE}<10mV $\gamma\Delta V_{BE}$<50mV/°C				200*	5.6	$C_c r_{bb'}$ 150ps	355	2素子複合
〃 1605	松下	SW	〃	−250	−250	−70	1.2W	150			110	−10	−5			t_r<0.3μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2μs							161	
〃 1606	三洋	〃	〃	−180	−160	−1.5A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−120	100	−5	−300	−10	50	t_{on}<1μs, t_f<3μs t_{stg}<1μs				100*	30		188	2SC4159とコンプリ
〃 1607	〃	〃	〃	−40	−20	−150	200	150	−0.1	−30	120	−1	−10	−10	10	t_r<20ns, t_f<25ns t_{stg}<180ns				400*	2.9		176	2SC4168とコンプリ
〃 1608	日電	〃	Si.E	−60	−40	−500	150	150	−0.1	−40	140	−2	−150			t_{on}<35ns, t_{off}<225ns t_{stg}<225ns							412	
〃 1609	〃	RF.AF	〃	−160	−160	−50	150	150	−0.1	−160	200	−3	−15	−10	10					80*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 25ps	412	
〃 1610	〃	SW	〃	−15	−15	−100	150	150	−0.1	−8	80	−1	−10			t_{on}<20ns, t_{off}<40ns t_{stg}<40ns							412	
〃 1611	〃	RF.AF	〃	−60	−50	−100	150	150	−0.1	−60	200	−6	−1	−6	10					180*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 35ps	412	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1612	日電	RF. AF	Si. E	−120	−120	−50	150	150	−0.05	−120	500	−6	−1	−6	1					90 *	2	20 *	412	
〃 1613	〃	SW	〃	−25	−10	−150	150	150	−0.1	−25	1000	−5	−1			t_{on}< 1 μs, t_f< 2 μs t_{stg}< 4 μs							412	
〃 1614	松下	〃	Si. TP	−400	−400	−500	25W (Tc=25°C)	150	−100	−400	180	−5	−100			t_{on}< 1 μs, t_f< 2 μs t_{stg}< 4 μs							364	
〃 1615	日電	〃	Si. E	−30	−20	−10A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−20	300	−2	−500			t_{on}<130ns, t_f<150ns t_{stg}<500ns							186	
〃 1616	三洋	〃	Si. EP	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	150	−5	−5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_B/R_{BE}=0.1±0.01)						200 *	5.5		92C	2SC4195とコンプリ
〃 1617	日立	RF. AF	〃	−55	−50	−100	150	150	−0.5	−20	200	−12	−2	−12	2					280 *	3	$C_r r_{bb'}$ 12ps	176	
〃 1618	東芝	〃	〃	−50	−50	−150	100	125	−0.1	−50	250	−6	−2	−10	1					150 *	4	30	73	2素子複合
〃 1619	松下	〃	〃	−30	−25	−500	1 W	150	−0.1	−20	210	−10	−150	−10	50					200 *	6	25	413	
〃 1620	東芝	〃	〃	−70	−60	−200	200	150	−0.1	−20	130	−2	−50	−2	50					150 *	9	5	176	
〃 1621	〃	〃	〃	−30	−25	−800	200	150	−0.1	−20	200	−1	−100	−5	10					120 *	19	25	176	
〃 1622	三洋	RF	〃	−55	−50	−150	100	150	−0.1	−35	180	−6	−1	−6	1					180 *	7	$C_r r_{bb'}$ 65ps	412	
〃 1623	〃	SW	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	250	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ)									92C	
〃 1624	〃	RF	〃	−250	−250	−100	500	150	−0.1	−200	190	−10	−1	−30	10					70 *	2.4	$C_r r_{bb'}$ 10ps	138	
〃 1625	日電	AF. PA. SW	Si. T	−400	−400	−500	750	150	−10	−400	80	−5	−50			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 5 μs							138	
〃 1626	〃	〃	〃	−400	−400	−2A	1 W	150	−10	−400	60	−5	−100			t_{on}<0.5μs, t_f<0.7μs t_{stg}< 2 μs							278	
〃 1627	〃	〃	〃	−600	−600	−1A	1 W	150	−10	−600	58	−5	−500			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							278	
〃 1628	日立	RF. AF	Si. EP	−30	−30	−100	100	150	−0.5	−20	300	−12	−2	−12	2					280 *	3.3	$C_r r_{bb'}$ 12ps	412	
〃 1629	〃	〃	〃	−55	−55	−100	100	150	−0.5	−30	500	−12	−2	−12	2					230 *	2	200	412	
〃 1630	三菱	〃	Si. E	−50	−50	−100	500	125	−0.5	−50	300	−6	−1	−6	10					200 *	2.5	$C_r r_{bb'}$ 300ps	175	
〃 1631																								
〃 1632																								
〃 1633	ローム	PA	Si. EP	−150	−150	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−10	−150	180	−5	−1A	−12	1 A					20 *	300	10	334	
〃 1634	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−80	120	−4	−1A	−12	500					12 *	80	7	268	
〃 1635	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−80	120	−4	−1A	−12	500					12 *	80	7	405	
〃 1636																								
〃 1637																								
〃 1638																								
〃 1639																								
〃 1640	日電	SW	Si. E	−30	−30	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−30	−120	−1	−3A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							370	
〃 1641	三洋	〃	Si. EP	−25	−20	−8A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−20	200	−2	−500			t_{on}<0.3μs, t_f<0.15μs t_{stg}<0.8μs							411	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1642																								
〃 1643	サンケン	PA	Si. EP	−50	−35	−7A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−50	70	−2	−5A	−12	1A					75 *	180	10	400	
〃 1644	日電	SW	Si. E	−150	−100	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	200	−2	−1A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs							268	
〃 1645	〃	〃	〃	−150	−100	−7A	35W (Tc=25°C)	150	−10	−100	200	−2	−1.5A			〃							268	
〃 1646	〃	〃	〃	−150	−100	−10A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	200	−2	−2A			〃							268	
〃 1647	〃	〃	〃	−150	−100	−5A	18W (Tc=25°C)	150	−10	−60	200	−2	−1A			〃							186	
〃 1648	〃	〃	〃	−100	−60	−5A	18W (Tc=25°C)	150	−10	−60	200	−2	−1A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							186	
〃 1649	〃	〃	〃	−40	−30	−7A	18W (Tc=25°C)	150	−10	−30	200	−2	−1.5A			〃							186	
〃 1650	〃	〃	〃	−150	−100	−5A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−100	200	−2	−1A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs							96	
〃 1651	〃	〃	〃	−150	−100	−7A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	200	−2	−1.5A			〃							96	
〃 1652	〃	〃	〃	−150	−100	−10A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	200	−2	−2A			〃							96	
〃 1653	三洋	〃	Si. EP	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	85	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_{BE}=10k±3kΩ)									176	
〃 1654	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	85	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_{BE}=10k±3kΩ)									92	
〃 1655	〃	〃	〃	−50	−50	−100	200	150	−0.1	−40	55	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_{BE}=4.7k±1.4kΩ)									176	
〃 1656	〃	〃	〃	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−40	55	−5	−10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_{BE}=4.7k±1.4kΩ)									92	
〃 1657	韓国電子	PA	Si. T	−150	−150	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−10	−120	75	−10	−500	−10	500					4 *	55		381	
〃 1658	〃	〃	Si. EP	−30	−30	−3A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−20	70~240	−2	−500	−2	500					100 *	40		381	
〃 1659	〃	〃	〃	−160	−160	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−160	70~240	−5	−100	−10	100					100 *	30		381	
〃 1660	〃	RF	〃	−150	−150	−50	500	150	−0.1	−150	70~240	−5	−10	−30	10					120 *	4		336	
〃 1661	〃	〃	〃	−120	−120	−800	500	150	−0.1	−120	80~240	−5	−100	−5	100					120 *	<30		336	
〃 1662	〃	〃	〃	−80	−80	−400	500	150	−0.1	−80	70~240	−2	−50	−10	10					120 *	14		336	
〃 1663	〃	AF	〃	−30	−30	−1.5A	500	150	−0.1	−30	100~320	−2	−500	−2	500					120 *	<50		336	
〃 1664	〃	〃	〃	−35	−30	−800	500	150	−0.1	−35	100~320	−1	−100	−5	10					120 *	19		336	
〃 1665																								
〃 1666																								
〃 1667																								
〃 1668																								
〃 1669																								
〃 1670																								
〃 1671																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)															外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)		
2SA1672																									
〃 1673																									
〃 1674	松下	AF	Si. EP	−80	−80	−1A	1 W (Tc=25°C)	150	−0.1	−40	200	−2	−100	−10	50					120*	10	30	259		
〃 1675																									
〃 1676																									
〃 1677																									
〃 1678																									
〃 1679																									
〃 1680																									
〃 1681																									
〃 1682																									
〃 1683																									
〃 1684																									
〃 1685																									
〃 1686																									
〃 1687																									
〃 1688																									
〃 1689																									
〃 1690																									
〃 1691																									
〃 1692																									
〃 1693																									
〃 1694																									
〃 1695																									
〃 1696																									
〃 1697																									
〃 1698																									
〃 1699																									
〃 1700																									
〃 1701																									

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB 12	富士通	AF	Ge. A	−30		−50	50	70	−15	−30				−6	1	−0.98*	30*	3.5*	0.4*	0.8			61	2S113
★	〃 13	〃	〃	〃	−30		−50	100	70	−15	−30				−6	1	−0.98*	30*	3.5*	0.4*	0.8			61	2S114
★	〃 14	〃	LN	〃	−30		−50	100	70	−15	−30				−6	1	−0.98*	30*	3.5*	0.4*	0.8	NF = 5 dB (f = 1 kHz)		61	2S115
★	〃 15	〃	AF	〃	−60		−50	100	70	−15	−60				−6	1	−0.98*	30*	3.5*	0.4*	0.8			61	2S116
★	〃 16	〃	PA	〃	−16		−600	1.8W (T_c=25°C)	70	−20	−5	50	−2	−50										93	2S119
★	〃 16A	〃	〃	〃	−20		−600	1.8W (T_c=25°C)	70	−20	−5	50	−2	−50										93	
★	〃 17	〃	〃	〃	−32		−600	1.8W (T_c=25°C)	70	−20	−5	50	−2	−50										93	2S120
★	〃 17A	〃	〃	〃	−40		−600	1.8W (T_c=25°C)	70	−20	−5	50	−2	−50										93	
★	〃 18	〃	〃	〃	−60		−600	1.8W (T_c=25°C)	70	−20	−5	50	−2	−50										93	2S121
★	〃 18A	〃	〃	〃	−80		−600	1.8W (T_c=25°C)	70	−20	−5	50	−2	−50										93	
★	〃 19	〃	〃	〃	−16		−2.5A	5.5W (T_c=25°C)	70	−100	−5	50	−2	−50										94	2S122
★	〃 20	〃	〃	〃	−32		−2.5A	5.5W (T_c=25°C)	70	−100	−5	50	−2	−50										94	2S123
★	〃 21	〃	〃	〃	−60		−2.5A	5.5W (T_c=25°C)	70	−100	−5	50	−2	−50										94	2S124
★	〃 22	三洋	〃	〃	−25		−200	300	85	−15	−20	100	−1.5	−100	−6	100						1		63	2SD30とコンプリ
★	〃 23	〃	AF	〃	−15		−10	40	75	−10	−15				−6	1	70	3000	6	30	1.5			12A	
★	〃 24	〃	〃	〃	−15		−15	100	75	−15	−15				−6	1	70	3000	6	30	1.5	12		12A	
★	〃 25	東芝	PA	〃	−60	−60R	−1.5A	20 W (T_c=25°C)	75	−160	−12	60	−1.5	−1A	−1.5	500					0.25			102	2S26A
★	〃 26	〃	〃	〃	−32	−32R	−1.5A	20 W (T_c=25°C)	75	−160	−12	60	−1.5	−1A	−1.5	500					0.25			102	2S 26
★	〃 26A	〃	〃	〃	−60		−1.5A	20 W (T_c=25°C)	75	−160	−12	60	−1.5	−1A	−1.5	500					0.25			102	
★	〃 27	ソニー	〃	〃	−15	−15R	−0.5A	5 W (T_c=25°C)	85	−800	−15	29	−1.5	−200							$f_{\alpha e}$ = 7kHz	200		102	2T305
★	〃 28	〃	〃	〃	−15	−15R	−0.5A	5 W (T_c=25°C)	85	−800	−15	68	−1.5	−200							$f_{\alpha e}$ = 7kHz	200		102	2T305
★	〃 29	〃	〃	〃	−15	−15R	−0.5A	5 W (T_c=25°C)	85	−800	−15	115	−1.5	−200							$f_{\alpha e}$ = 7kHz	200		102	2T305
★	〃 30	〃	〃	〃	−15	−15R	−0.5A	5 W (T_c=25°C)	85	−800	−15	68	−1.5	−200							$f_{\alpha e}$ = 7kHz	200		102	2T306
★	〃 31	〃	〃	〃	−15	−15R	−0.5A	5 W (T_c=25°C)	85	−800	−15	115	−1.5	−200							$f_{\alpha e}$ = 7kHz	200		102	2T306
★	〃 32	富士通	AF	〃	−20		−50	150	85	−14	−12				−9		40	1500	4.2	16.5	0.8			12A	2S 32
★	〃 33	〃	PA	〃	−20		−50	150	85	−14	−12	70	−1	−50	−6	1	80	2600	5.5	20.8	1			12A	2SD33とコンプリ
★	〃 34	〃	〃	〃	−20		−150	250	85	−14	−12	70	−1	−150	−6	1	85	2450	4.9	22.5	0.8			71A	2SD34とコンプリ
★	〃 37	〃	〃	〃	−30	−20R	−50	150	85	−14	−30	70	−1	−50	−6	1	80	2600	5.5	20.8	1			12A	2SD37とコンプリ
★	〃 38	〃	〃	〃	−30		−150	250	85	−16	−30	70	−1	−150	−6	1	85	2450	4.9	22.5	0.8			71A	2SD38とコンプリ
★	〃 39	〃	LN	〃	−10		−2	50	85	−10	−10				−4	0.5	65	3570	9.44	25	NF = 4 dB (f = 1 kHz)			12A	2S 39

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SB 40	東芝	SW	Ge.A	−40	−30S	−100	80	75	−10	−12	100	−1	−100	−6	1		t_r=0.55μs, t_f=0.35μs t_s=0.6μs			>0.7	<50	<180	12A		
★	〃 41	富士通	PA	〃	−40	−32S	−1.2A	44 W (Tc=25°C)	91	−2mA	−30	65	−1.5	−1A	−14.4	50		PG = 30 dB Po = 10 W	(B級 PP Zl = 24Ω)					102	2S 41	
★	〃 42	〃	〃	〃	−60	−50S	−1.2A	44 W (Tc=25°C)	91	−2mA	−30	65	−1.5	−1A	−14.4	50		PG = 30 dB Po = 10W	(B級 PP Zl = 24Ω)					102	2S 42	
★	〃 43	東芝	〃	〃	−25	−25R	−50	150	75	−10	−12	70	−1	−50	−6	1					1	35		12A	2SD43 とコンプリ	
★	〃 43A	〃	〃	〃	−45		−150	150	75	−10	−12	70	−1	−50	−6	1					1	35		12A	2SD43A とコンプリ	
★	〃 44	〃	AF	〃	−30		−50	80	75	−10	−12				−6	1	85	2500	5	30	>0.5	30		12A	2SD44 とコンプリ	
★	〃 46	〃	〃	〃	−25		−50	80	75	−5	−12				−6	1	140	4200	6	30		35		12A	2S 46	
★	〃 47	〃	LN	〃	−25		−50	80	75	−14	−25				−6	1	140	4200	6	30	NF < 5 dB (f = 1 kHz)			12A	2S 47	
★	〃 48	ソニー	AF.PA	〃	−16	−16R	−100	140	65	−16	−16	43	−1	−20	−6	1	−0.973*	28*	8*	0.6*	2.5	25		84A	2T 31	
★	〃 49	〃	〃	〃	−16	−16R	−100	140	65	−16	−16	83	−1	−20	−6	1	−0.985*	28*	8*	0.6*	3.0	25		84A	2T 31	
★	〃 50	〃	〃	〃	−16	−16R	−100	140	65	−16	−16	131	−1	−20	−6	1	−0.990*	28*	8*	0.6*	3.5	25		84A	2T 31	
★	〃 51	〃	PA	〃	−30	−20R	−200	200	85	−16	−25	43	−1	−20	−6	1	−0.973*	28*	8*	0.6*	2.0	25		84A	2T 32	
★	〃 52	〃	〃	〃	−30	−20R	−200	200	85	−16	−25	83	−1	−20	−6	1	−0.985*	28*	8*	0.6*	3.0	25		84A	2T 32	
★	〃 53	〃	〃	〃	−30	−30R	−250	200	85	−10	−30	70	−1	−20	−6	1	−0.982*	28*	7*	0.6*	3.0	25		84A	2T 38	
★	〃 54	東芝	AF	〃	−30	−20R	−150	150	75	−14	−30				−6	1	80~300	4200	6	30	1*	35	120	12A	2S 54	
★	〃 55	〃	PA	〃	−60		−50	150	75	−14	−25	80	−1	−50	−6	1					1	35		12A	2S56A	
★	〃 56	〃	〃	〃	−30	−25R	−150	150	75	−14	−30	80	−1	−50	−6	1					1	35	120	12A	2S 56	
★	〃 56A	〃	〃	〃	−45		−150	150	75	−14	−25	80	−1	−50	−6	1					1	35		12A		
★	〃 57	富士通	AF	〃	−30	−20R	−100	100	70	−15	−30				−6	1	70	30*	3*	0.3*				84B		○
★	〃 58	〃	〃	〃	−12		−50	100	70	−15	−12				−6	1	−0.98*	30*	3*	0.3*				78		
★	〃 59	〃	SW	〃	−30		−100	150	85	−15	−30	70	−1	−50										84B		
★	〃 60	〃	AF	〃	−20	−20S	−50	150	85	−14	−12				−6	1	70	30*	3*	0.3*				12A		
★	〃 60A	〃	〃	〃	−20		−50	150	85	−14	−12	70	−1	−50										12A		
★	〃 61	〃	〃	〃	−30		−50	150	85	−10	−30				−6	1	85	3000	7	30	1	40		12A	2S 61	
★	〃 62	東芝	PA	〃	−60	−60R	−500	2 W (Tc=55°C)	75	−70	−12	60	−1	−500	−1	100					0.4			101		
★	〃 63	〃	〃	〃	−32	−32R	−500	2 W (Tc=55°C)	75	−70	−12	60	−1	−500	−1	100					0.4			101		
★	〃 64	〃	〃	Ge.D	−100	−100R	−6A	25 W (Tc=25°C)	75	−330	−12	70	−1.5	−1A	−1.5	500					1			102		
★	〃 65	富士通	SW	Ge.A	−30	−20R	−100	150	85	−15	−30				−6	1	65	t_r = 3 μs, t_f = 4 μs t_s = 3 μs			1	40		12A	2S 65	
★	〃 66	日立	AF	〃	−30	−20	−50	100	85	−15	−30				−6	1	−0.984*	30*	< 8*	0.38*	PG > 24 dB (f = 1 kHz)			12C	2S 11 2N215C	
★	〃 67	〃	PA	〃	−55	−32	−150	350 (放熱板付)	70	−10	−12	·63	−1	−150	−6	1	45	1360	2.1	21	1	45	70	66	2S193 HJ 43	○

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB 68	日立	SW	Ge. A	−105	−105S	−100	50	85	−14	−2.5	60	−0.35	−5										84 A	2N398
★	〃 69	東芝	PA	Ge. D	−60	−60R	−6 A	25 W (Tc=25°C)	75	−330	−12	70	−1.5	−1 A	−1.5	500					1			102	
★	〃 70	松下	AF	Ge. A	−30		−10	125	75	−12	−10				−2	0.5	30	2200	9	23	f_{ae}= 15kHz			20	OC 70
★	〃 71	〃	〃	〃	−30		−10	125	75	−12	−10				−2	3	50	800	5.4	80	f_{ae}= 15kHz			20	OC 71
★	〃 73	日立	LN	〃	−10		−2	20	85	−7	−10				−4	0.5	65	3900	3.8	11.8	NF < 6 dB (f= 1 kHz)			12 A	2N220
★	〃 74	〃	AF	〃	−16		−15	80	85	−6	−12				−6	1	48							12 A	2S148 HJ 62
★	〃 75	〃	〃	〃	−25	−25S	−100	150	85	−14	−30	65	−1.5	−50	−6	1	55	1750	3	17.5	2			12C	2SD75 とコンプ
★	〃 75A	〃	〃	〃	−45	−45S	−100	150	85	−25	−45	65	−1.5	−50	−6	1	55	1750	3	17.5	2			12 A	2SD75A とコンプ
★	〃 76	〃	〃	〃	−12		−100	150	85	−14	−12	65	−1.5	−50	−6	1	55	1750	3	17.5	2			12 A	2N406
★	〃 77	〃	PA	〃	−25	−25S	−100	150	85	−14	−25	85	−1	−50	−6	1	70	1900	3.8	26	2			12 C	2SD77 とコンプ
★	〃 77A	〃	〃	〃	−45	−45S	−100	150	85	−25	−45	85	−1	−50	−6	1	70	1900	3.8	26	2			12 C	2SD77A とコンプ
★	〃 78	〃	〃	〃	−12	−12S	−100	150	85	−14	−12	85	−1.5	−50	−6	1	70							12 A	2N408 HJ 51
★	〃 79	〃	〃	〃	−25		−150	250	85	−16	−30	70	−1	−150										70	2S 91 HJ34A
★	〃 80	〃	〃	〃	−25		−1 A	4 W (Tc=41°C)	85	−100	−12	70	−1.5	−0.5A										101	2S177 HJ 36
★	〃 81	〃	〃	〃	−80		−0.5A	2 W (Tc=25°C)	85	−50	−50	45	−2	−100	−6	100	40	40	6	1200	0.5	40		101	2S177 HJ 47
★	〃 82	〃	〃	〃	−100		−0.5A	2 W (Tc=25°C)	85	−35	−50	40	−2	−100	−6	100	40	40	6	1200	0.5	40		101	2S177 HJ 47
★	〃 83	〃	〃	〃	−40	−32S	−3 A	11 W (Tc=80°C)	91	−3mA	−40	70	−1.5	−0.7A										102	2N301
★	〃 84	〃	〃	〃	−60	−32S	−3 A	11 W (Tc=80°C)	91	−3mA	−60	70	−1.5	−0.7A										102	2N301A
★	〃 85	〃	〃	〃	−40	−25	−10A	50 W (Tc=25°C)	91	−3mA	−40	30	−1.5	−4 A										102	HS102
★	〃 86	〃	〃	〃	−60	−35	−10A	50 W (Tc=25°C)	91	−3mA	−60	30	−1.5	−4 A										102	HS102
★	〃 87	〃	〃	〃	−80	−50	−10A	50 W (Tc=25°C)	91	−3mA	−80	30	−1.5	−4 A										102	HS102
★	〃 88	〃	〃	〃	−100	−65	−10A	50 W (Tc=25°C)	91	−3mA	−100	30	−1.5	−4 A										102	HS102
★	〃 89	〃	〃	〃	−25		−150	250	85	−16	−25	70	−1	−150	−6	1	55	1800	3.3	20				71 A	
★	〃 89A	〃	〃	〃	−45	−45S	−150	250	85	−50	−45	70	−1	−150	−6	1	55	1800	3.3	20				71 A	
★	〃 90	東芝	AF	〃	−18		−5	40	75	−14	−18				−6	1	70	30*	3.5*	0.4*	>1	12		5	
★	〃 91	〃	PA	〃	−18		−30	40	75	−14	−18	70	−1	−30	−6	1					>1			5	
★	〃 92	松下	〃	〃	−32		−125	125	75	−12	−10	50	−1	I_B= −2mA	−6	10					0.35			16	OC 72
★	〃 93	〃	AF	〃	−30		−10	125	75	−12	−20				−2	3	90							20	MC 75
★	〃 94	東芝	PA	〃	−25		−50	150	75	−14	−25	80	−1	−50	−6	1					1	35		12 A	2S 56
★	〃 95	〃	〃	〃	−25		−50	150	75	−14	−30	60	−1	−50										12 A	

2SB

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SB 96	松下	PA	Ge. A	−32		−125	125	75	−12	−10	80	−1	I_B= −2mA										16	OC 76
★	〃 97	東芝	LN	〃	−18		−5	40	75	−14	−30				−6	1	70	NF = 4 dB (V_{CE}= −3V, I_E= 0.5mA, f = 1kHz)						5	
★	〃 98	日電	AF	〃	−30	−25R	−50	125	75	−20	−6	35	−1	−50	−6	1	40	30*	3.5*	0.3*	1	35		84A	ST340
★	〃 99	〃	AF	〃	−30	−25R	−50	125	75	−20	−6	130	−1	−50	−6	1	120	30*	3.5*	0.25*	1.5	35		84A	ST340
★	〃 100	〃	LN	〃	−30	−25R	−50	100	75	−10	−30				−6	1	60	30*	2.5*	0.3*	1.2	NF = 3.5dB (f = 1kHz)		84A	2S100 ST34H
★	〃 101	〃	AF. PA	〃	−30	−25R	−50	125	75	−10	−30				−6	1	60	30*	2.5*	0.3*	1.2	35		84A	2S101 ST34F
★	〃 102	〃	〃	〃	−30	−25R	−50	180	75	−10	−30				−6	1	60	30*	2.5*	0.3*	1.2	35		91	2S102 ST34FR
★	〃 103	〃	〃	〃	−30	−25R	−100	125	75	−10	−30	70	−1	−50	−6	1		P_o=400mW PG=25dB (B級 PP Z_l=300Ω)			1.2			84A	2S103 ST34G
★	〃 104	〃	〃	〃	−30	−25R	−100	180	75	−10	−30	70	−1	−50	−6	1		P_o=400mW PG=25dB (B級 PP Z_l=300Ω)			1.2			91	2S104 ST34GR
★	〃 105	〃	〃	〃	−30	−30S	−500	500	75	−100	−30	70	−2	−200	−2	200					0.5			81	2S105 ST35
★	〃 106	〃	〃	〃	−30	−30S	−500	3 W (放熱板付)	75	−100	−30	70	−2	−200	−2	200					0.5			95	2S106 ST35R
★	〃 107	〃	〃	〃	−30	−25	−2A	10 W (T_c=25°C)	75	−500	−30	70	−2	−1A	−2	200		P_o= 7 W PG=30dB (B級 PP Z_l= 25Ω)			0.4			102	2S107 ST36
★	〃 107A	〃	〃	〃	−60	−35	−3A	20 W (T_c=25°C)	75	−500	−60	70	−2	−1A	−2	200		P_o= 7 W PG=30dB (B級 PP Z_l= 25Ω)			0.4			102	2S107 ST36A
★	〃 108	〃	PA	〃	−40		−500	500	75	−100	−40	70	−2	−200	−2	200					0.5			81	
★	〃 108A	〃	〃	〃	−60		−500	500	75	−100	−60	70	−2	−200	−2	200					0.5			81	
★	〃 108B	〃	〃	〃	−80		−500	500	75	−100	−80	70	−2	−200	−2	200					0.5			81	
★	〃 109	〃	〃	〃	−40		−500	3 W (放熱板付)	75	−100	−40	70	−2	−200	−2	200					0.5			95	
★	〃 109A	〃	〃	〃	−60		−500	3 W (放熱板付)	75	−100	−60	70	−2	−200	−2	200					0.5			95	
★	〃 109B	〃	〃	〃	−80		−500	3 W (放熱板付)	75	−100	−80	70	−2	−200	−2	200					0.5			95	
★	〃 110	〃	AF	〃	−25		−50	100	85	−10	−6				−6	1	30	30*	2.5*	0.5*	1			19A	ST330
★	〃 111	〃	〃	〃	−25		−50	100	85	−10	−6				−6	1	45	30*	2.5*	0.5*	1			19A	ST331
★	〃 112	〃	〃	〃	−25		−50	100	85	−10	−6				−6	1	60	30*	2.5*	0.5*	1			19A	ST332
★	〃 113	〃	〃	〃	−25		−50	100	85	−10	−6				−6	1	80	30*	2.5*	0.5*	1			19A	ST333
★	〃 114	〃	PA	〃	−25	−20R	−50	100	85	−10	−6	65	−1	−20	−6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5			19A	ST381
★	〃 115	〃	〃	〃	−25	−20R	−50	100	85	−10	−6	85	−1	−20	−6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5			19A	ST382
★	〃 116	〃	〃	〃	−25	−20R	−50	100	85	−10	−6	110	−1	−20	−6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5			19A	ST383
★	〃 117	〃	〃	〃	−25	−20R	−50	100	85	−10	−6	140	−1	−20	−6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5			19A	
★	〃 118	松下	〃	〃	−15		−1.5A	50 W (T_c=25°C)	75	−100	−14	60	−7	−0.3A	−7	300					0.2			102	
★	〃 119	〃	〃	〃	−32		−1.5A	50 W (T_c=25°C)	75	−100	−14	60	−7	−0.3A	−7	300					0.2			102	OC 19
★	〃 120	富士通	AF	〃	−32		−20	150	85	−6.5	−12				−12	2	70	PG = 41 dB P_o = 5 mW (A級S)						12A	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SB121	富士通	SW	Ge. A	−105	−50	−100	50	85	−14	−2.5	60	−0.35	−5	−6	1					0.5			12A		
★	〃 122	東芝	〃	〃	−80	−80R	−1.5A	20 W (Tc=25°C)	75	−160	−12	60	−1.5	−1A	−1.5	500					0.25			102		
★	〃 123	〃	〃	〃	−40	−20R	−5A	20 W (Tc=25°C)	75	−1mA	−40										0.25	<300	<40	102		
★	〃 124	〃	〃	〃	−60	−60S	15A	40 W (Tc=25°C)	75	−1.2mA	−12	70	−1.5	−15A	−6	500					0.3			107		
★	〃 125	〃	〃	〃	−36	−36S	−15A	40 W (Tc=25°C)	75	−1.2mA	−12	70	−1.5	−15A	−6	500					0.3			107		
★	〃 126	松下	PA	〃	−32		−3.5A	30W (Tc≦45°C)	90	−220	−14	35	−1	−1 A	−6	1 A					$f_{\alpha e}$= 6kHz			102	OC 26	○
★	〃 127	〃	〃	〃	−32		−3.5A	30W (Tc≦45°C)	90	−220	−14	75	−1	−1 A	−6	1 A					$f_{\alpha e}$= 6kHz			102	OC 27	○
★	〃 128	〃	〃	〃	−80		−6A	30W (Tc≦45°C)	90	−220	−14	40	−1	−1 A										102	OC 28	
★	〃 128A	〃	〃	〃	−120		−6A	54 W (Tc=25°C)	90	−200	−14	50	−1	−1 A										102		
★	〃 129	〃	〃	〃	−80		−6A	54 W (Tc=25°C)	90	−200	−14	85	−1	−1 A										102	OC 29	
★	〃 129A	〃	〃	〃	−120		−6A	54 W (Tc=25°C)	90	−200	−14	85	−1	−1 A										102		
★	〃 130	〃	〃	〃	−32		−1.5A	6.5 W (Tc=25°C)	75	−200	−14	60	−7	−0.3	−7	300					0.2			100	OC 30	
★	〃 131	富士通	〃	〃	−40	−32S	−1.5A	65 W (Tc=25°C)	90	−2mA	−30	65	−1.5	−1A	−14.4	50		PG = 30dB (B級PP P_o = 12W Z_l = 24Ω)			$f_{\alpha e}$= 5kHz			102	2S131	
★	〃 131A	〃	〃	〃	−40	−32S	−1.5A	65 W (Tc=25°C)	90	−2mA	−30	65	−1.5	−1A							$f_{\alpha e}$= 5kHz			102		
★	〃 132	〃	〃	〃	−60	−50S	−1.5A	65 W (Tc=25°C)	90	−2mA	−30	65	−1.5	−1A	−14.4	50		PG = 30dB (B級PP P_o = 12W Z_l = 24Ω)			$f_{\alpha e}$= 5kHz			102		
★	〃 134	三菱	AF. LN	〃	−30	−30S	−100	100	85	−10	−25				−6	1	70	2100	3.2	21	NF = 4 dB (f = 1kHz, I_C = 0.5mA)			12B		
★	〃 135	〃	AF	〃	−30	−30S	−100	100	85	−10	−25				−6	1	70	2100	3.2	21				12B		
★	〃 136	〃	PA	〃	−25	−25S	−150	150	85	−10	−25	120	−1.5	−50										12B		○
★	〃 137	〃	〃	〃	−30	−25R	−5A	30 W (Tc=25°C)	85	−500	−20	80	−1.5	−1A										102		
★	〃 138	〃	〃	〃	−60	−30R	−5A	30 W (Tc=25°C)	85	−500	−30	80	−1.5	−1A										102		
★	〃 140	ソニー	〃	〃	−40	−40R	−1.5A	12 W (Tc=25°C)	85	−600	−40	74	−1.5	−1A							$f_{\alpha e}$= 7kHz	200		102	2T301	
★	〃 141	〃	〃	〃	−60	−60R	−1.5A	12 W (Tc=25°C)	85	−600	−60	74	−1.5	−1A							$f_{\alpha e}$= 7kHz	200		102	2T302	
★	〃 142	〃	〃	〃	−30	−30R	−1A	10 W (Tc=25°C)	85	−1mA	−30	24	−1.5	−1A							$f_{\alpha e}$= 7kHz	200		102	2T303	
★	〃 143	〃	〃	〃	−30	−30R	−1A	10 W (Tc=25°C)	85	−1mA	−30	37	−1.5	−1A							$f_{\alpha e}$= 7kHz	200		102	2T303	
★	〃 144	〃	〃	〃	−30	−30R	−1A	10 W (Tc=25°C)	85	−1mA	−30	75	−1.5	−1A							$f_{\alpha e}$= 7kHz	200		102	2T303	
★	〃 145	〃	〃	〃	−30	−30R	−1A	10 W (Tc=25°C)	85	−1mA	−30	37	−1.5	−1A				(ペアー品種)			$f_{\alpha e}$= 7kHz	200		102	2T304	
★	〃 146	〃	〃	〃	−30	−30R	−1A	10 W (Tc=25°C)	85	−1mA	−30	75	−1.5	−1A				(ペアー品種)			$f_{\alpha e}$= 7kHz	200		102	2T304	
★	〃 147	〃	〃	〃	−60	−60R	−1.5A	12 W (Tc=25°C)	85	−600	−50	60	−1.5	−200							$f_{\alpha e}$= 7kHz	200		102		
★	〃 148	東芝	SW	〃	−80	−80S	−15A	40 W (Tc=25°C)	75	−1.2mA	−12	70	−1.5	−15A	−6	0.5A					0.3			107		
★	〃 149	〃	〃	〃	−40	−20R	−8A	25 W (Tc=25°C)	75	−230	−12	60	−1.5	−8A	−1.5	0.5A					0.25	<400	< 30	102		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB150	東芝	SW	Ge. A	−105	−40S	− 40	50	75	− 50	−105	35	−0.35	− 5	− 6	1					0.5	< 20	<370	12A	2S150
★	〃 151	富士通	〃	〃	− 80	−60R	−5A	50 W (Tc=25°C)	100	−500	− 30	40	−1.5	− 3A	−1.5	1 A					f_{ae}= 5kHz			102	
★	〃 152	〃	〃	〃	−100	−80R	−5A	50 W (Tc=25°C)	100	−500	− 30	40	−1.5	− 3A	−1.5	1 A					f_{ae}= 5kHz			102	
★	152A	〃	〃	〃	−100	−65R	−5A	50 W (Tc=25°C)	100	−3mA	−100	70	− 1	− 1A							f_{ae}= 4.5kHz			102	
★	〃 153	日立	AF	〃	− 12		− 70	150	85	− 14	− 12				− 3	1	70	2200	5	35				12A	
★	〃 154	〃	PA	〃	− 12		− 70	150	85	− 14	− 12	70	−1.5	− 50										12A	
★	〃 155	〃	AF	〃	− 16		−300	150	85	− 14	− 12				− 4	1	30	875	1.66	10.7	1.4			12A	
★	〃 156	〃	PA	〃	− 16		−300	150	85	− 14	− 12	70	− 1	−150	− 4	1	45	P_o=600mW PG = 27dB (B級 PP Z_l=86Ω)						12A	
★	156A	〃	〃	〃	− 20		−300	150	85	− 14	− 20	70	− 1	−150	− 4	1	45							12A	
★	〃 157	松下	AF	〃	− 7		− 5	10	55	− 10	− 2				−0.5	0.25	35				f_{ae}= 10kHz			2A	OC 57
★	〃 158	〃	〃	〃	− 7		− 5	10	55	− 10	− 2				−0.5	0.25	55				f_{ae}= 10kHz			2A	OC 58
★	〃 159	〃	AF	〃	− 7		− 5	10	55	− 10	− 2				−0.5	0.25	80				f_{ae}= 10kHz			2A	OC 59
★	〃 160	〃	PA	〃	− 7		− 5	10	55	− 10	− 2	75	− 2	−0.5										2A	OC 60
★	〃 161	日電	〃	〃	− 30		−100	125	75	− 10	− 6	50	− 1	− 50	− 6	1					0.65			84A	2S161 ST341
★	〃 162	〃	〃	〃	− 30		−100	180	75	− 10	− 6	50	− 1	− 50	− 6	1					0.65			91	2S162 ST341R
★	〃 163	〃	〃	〃	− 30		−100	125	75	− 10	− 6	70	− 1	− 50	− 6	1					0.8			84A	2S163 ST342
★	〃 164	〃	〃	〃	− 30		−100	180	75	− 10	− 6	70	− 1	− 50	− 6	1					0.8			91	2S164 ST342R
★	〃 165	〃	〃	〃	− 30		−100	125	75	− 10	− 6	100	− 1	− 50	− 6	1					1			84A	2S165 ST343
★	〃 166	〃	〃	〃	− 30		−100	180	75	− 10	− 6	100	− 1	− 50	− 6	1					1			91	2S166 ST343R
★	〃 168	富士通	AF	〃	− 9		−100	150	85	− 14	− 9				− 3	1	60	1300	4.9	20	0.8			12A	
★	〃 169	〃	PA	〃	− 9		−100	150	85	− 14	− 9	80	− 1	− 50	− 3	1		PG = 22dB P_o=100mW (B級 PP Z_l=100Ω)						12A	
★	〃 170	松下	AF	〃	− 30		−100	125	85	− 12	− 10				− 6	1	30							12B	OC 70
★	〃 171	〃	〃	〃	− 30		−100	125	85	− 12	− 10				− 6	1	60							12B	OC 71
★	〃 172	〃	PA	〃	− 32		−125	125	85	− 12	− 10	50	− 1	I_B= −2mA	− 6	10					0.35			12B	2SD31 とコンプリ
★	〃 173	〃	LN	〃	− 30		−100	125	85	− 12	− 10				− 6	1	100							12B	2S 74
★	〃 174	〃	PA	〃	− 20		−300	225	75	− 20	− 12	65	−0.5	−300	− 6	50					1.5			12B	OC 74
★	〃 175	〃	AF	〃	− 30		−100	125	85	− 12	− 10				− 6	1	100							12B	OC 75
★	〃 176	〃	PA	〃	− 32		−125	125	85	− 12	− 10	90	− 1	I_B= −2mA										12B	2SD32 とコンプリ
★	〃 177	〃	〃	〃	− 60		−125	125	85	− 12	− 10	90	− 1	I_B= −2mA										12B	OC 77
★	〃 178	〃	〃	〃	− 20		−300	225	85	− 20	− 12	56	V_{CB}=0V	−300										17	2SD178 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB178A	松下	PA	Ge. A	−40		−320	225	85	−20	−12	56	V_{CB}=0V	−300										17	2SD178A とコンプリ
★	〃 179	東芝	AF	〃	−25		−50	80	75	−14	−30				−6	1	50							12 A	2S179
★	〃 180	富士通	PA	〃	−40	−30S	−0.5A	5.5 W (Tc=25°C)	92	−1mA	−40	70	−1.5	−500	−12	15		PG = 26dB (B級PP) P_o = 4W (Z_l = 60Ω)						83	
★	〃 180A	〃	〃	〃	−40	−30S	−0.5A	12 W (Tc=25°C)	90	−500	−30	70	−1.5	−500							f_{ae} = 13kHz			83	
★	〃 181	〃	〃	〃	−60	−40S	−0.5A	5.5 W (Tc=25°C)	92	−1mA	−60	70	−1.5	−500	−12	15		PG = 26dB (B級PP) P_o = 4 W (Z_l = 60Ω)						83	
★	〃 181A	〃	〃	〃	−60	−40S	−0.5A	12 W (Tc=25°C)	90	−200	−30	70	−1.5	−500							f_{ae} = 13kHz			83	
★	〃 183	日立	AF	〃	−12		−20	50	85	−12	−12				−0.5	0.25	55							3	
★	〃 184	〃	PA	〃	−12		−20	50	85	−12	−12	100	−2	−5										3	
★	〃 185	三洋	〃	〃	−25		−150	200	85	−15	−20				−6	1	45	2000	5	20	1			12 B	
★	〃 186	〃	〃	〃	−25		−150	200	85	−15	−20				−6	1	120	6000	13	40	1	25		12 B	2SD186 とコンプリ
★	〃 187	〃	〃	〃	−25		−150	200	85	−15	−20				−6	1					1			12 B	2SD187 とコンプリ
★	〃 188	〃	〃	〃	−25		−150	200	85	−15	−20				−6	1	20				1			12 B	2S188
★	〃 189	東芝	〃	〃	−25		−250	250	75	−14	−25	75	−1	−100	−6	1					1			62	2S189
★	〃 190	沖	AF	〃	−25		−50	90	80	−15	−25				−6	1	150	PG = 45 dB (f = 1 kHz)						12 A	
★	〃 191	〃	〃	〃	−25		−50	90	80	−15	−25				−6	1	70	PG = 43 dB (f = 1 kHz)						12 A	
★	〃 192	〃	〃	〃	−25		−50	90	80	−15	−25				−6	1	35	PG = 41 dB (f = 1 kHz)						12 A	
★	〃 193	〃	〃	〃	−25		−100	200	80	−15	−25				−6	1	150	PG = 45 dB (f = 1 kHz)						75	
★	〃 194	〃	〃	〃	−25		−100	200	80	−15	−25				−6	1	70	PG = 43 dB (f = 1 kHz)						75	
★	〃 195	〃	〃	〃	−25		−100	200	80	−15	−25				−6	1	35	PG = 41 dB (f = 1 kHz)						75	
★	〃 196	〃	〃	〃	−30	−25R	−500	500	80	−100	−30	50	−2	−200										81	
★	〃 197	〃	〃	〃	−50	−35R	−500	500	80	−100	−50	50	−2	−200										81	
★	〃 198	沖	〃	〃	−70	−45R	−500	500	80	−100	−70	50	−2	−200										81	
★	〃 199	富士通	PA	〃	−12		−300	250	85	−14	−12	80	−1	−150	−3	1		PG = 22dB (B級PP) P_o=250mW (Z_l = 50Ω)						71 A	
★	〃 200	東芝	〃	〃	−32	−32R	−400	225	75	−40	−12	75	−1	−150	−1	100					0.5			77	2SD100 とコンプリ
★	〃 201	〃	SW	〃	−35		−400	300	75	−30	−12	150	−1	−150	−1	100		t_r=0.6μs, t_f=0.7μs t_s= 5 μs			0.5			84 A	
★	〃 202	〃	PA	〃	−32	−32R	−400	225	75	−40	−12	140	−1	−150	−1	100					0.5			77	
★	〃 203	新電元	〃	〃	−40	−30S	−20A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−40	40	−1.5	−15A										266	L10
★	〃 204	〃	〃	〃	−40	−30S	−30A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−40	100	−1.5	−15A										266	
★	〃 205	〃	〃	〃	−80	−60S	−20A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−80	40	−1.5	−15A	−6	2 A					f_{ae} = 2.5kHz			266	H10
★	〃 206	〃	〃	〃	−80	−60S	−30A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−80	100	−1.5	−15A	−6	2 A					f_{ae} = 2.5kHz			266	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SB 207	新電元	PA	Ge. A	−100	−75S	−20A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−100	40	−1.5	−15A										266		○
★	〃 208	〃	〃	〃	−100	−75S	−30A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−100	100	−1.5	−15A										266		○
★	〃 209	〃	〃	〃	− 40	−30S	−20A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	− 40	40	−1.5	−15A	− 6	2 A					f_{oe}= 2.5kHz			266	L 15 A	
★	〃 210	〃	SW	〃	− 40	−30S	−30A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	− 40	100	−1.5	−15A	− 6	2 A					f_{oe}= 2.5kHz			266	L 15 B	
★	〃 211	〃	〃	〃	− 80	−60S	−20A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	− 80	40	−1.5	−15A	− 6	2 A					f_{oe}= 2.5kHz			266	H 15 A	
★	〃 212	〃	〃	〃	− 80	−60S	−30A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	− 80	100	−1.5	−15A	− 6	2 A					f_{oe}= 2.5kHz			266	H 15 B	
★	〃 213	〃	〃	〃	−100	−75S	−20A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−100	40	−1.5	−15A	− 6	2 A					f_{oe}= 2.5kHz			266	U 15 A	○
★	〃 214	〃	〃	〃	−100	−75S	−30A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−100	100	−1.5	−15A	− 6	2 A					f_{oe}= 2.5kHz			266	U 15 B	○
★	〃 215	三洋	〃	〃	−100	−100R	− 3 A	24 W (Tc=25°C)	85	−500	− 12	100	−1.5	− 1 A	− 3	100					<0.15	<400	<50	102		
★	〃 216	〃	PA	〃	− 60		− 3 A	24 W (Tc=25°C)	85	−500	− 12	80	−1.5	−200	−1.5	200					0.25			102		○
★	〃 217	〃	PA	〃	− 25		− 3 A	24 W (Tc=25°C)	85	−500	− 12	80	−1.5	− 1 A	−1.5	200					0.5			102		
★	〃 218	日電	SW	〃	− 80	−50X	−500	225	85	− 10	− 50	50	− 1	−100	− 5	1					2.5	<30	<200	84 A		
★	〃 219	〃	PA	〃	− 30	−20R	−200	225	85	− 16	− 25	31	− 1	− 20	− 6	1		30 *			1.5	25		84 A	2SD19 とコンプリ	
★	〃 219A	〃	〃	〃	− 30	−20R	−500	225	85	− 16	− 25	31	− 1	− 20	− 5	1					1.5			84 A		
★	〃 220	〃	〃	〃	− 30	−20R	−200	225	85	− 16	− 25	50	− 1	− 20	− 6	1		30 *			2	25		84 A	2SD20 とコンプリ	
★	〃 220A	〃	〃	〃	− 30	−20R	−500	225	85	− 16	− 25	50	− 1	− 20	− 5	1					2			84 A		
★	〃 221	〃	〃	〃	− 30	−20R	−200	225	85	− 16	− 25	72	− 1	− 20	− 6	1		30 *			2	25		84 A	2SD21 とコンプリ	
★	〃 221A	〃	〃	〃	− 30	−20R	−500	225	85	− 16	− 25	72	− 1	− 20	− 5	1					2.5			84 A		
★	〃 222	〃	〃	〃	− 30	−20R	−200	225	85	− 16	− 25	97	− 1	− 20	− 6	1		30 *			2.5	25		84 A	2SD22 とコンプリ	
★	〃 222A	〃	〃	〃	− 30	−20R	−500	225	85	− 16	− 25	97	− 1	− 20	− 5	1					2.8			84 A		
★	〃 223	〃	〃	〃	− 30	−20R	−200	225	85	− 16	− 25	150	− 1	− 20	− 6	1		30 *			3.0	25		84 A	2SD23 とコンプリ	
★	〃 223A	〃	PA	Ge. A	− 30	−20R	−500	225	85	− 16	− 25	150	− 1	− 20	− 5	1					3			84 A		
★	〃 224	〃	〃	〃	− 45	−30R	−500	225	85	− 10	− 30	35	− 1	− 20	− 5	1	30	31 *	4 *	0.65 *	2	25		84 A	2N524	
★	〃 225	〃	〃	〃	− 45	−30R	−500	225	85	− 10	− 30	52	− 1	− 20	− 5	1	44	31 *	5 *	0.6 *	2.5	25		84 A	2N525	
★	〃 226	〃	〃	〃	− 45	−30R	−500	225	85	− 10	− 30	73	− 1	− 20	− 5	1	64	30 *	6.5 *	0.42 *	3	25		84 A	2N526	
★	〃 227	〃	〃	〃	− 45	−30R	−500	225	85	− 10	− 30	91	− 1	− 20	− 5	1	81	29 *	8 *	0.37 *	3.3	25		84 A	2N527	
★	〃 228	日立	〃	〃	− 80	−35	− 5 A	50 W (Tc=25°C)	91	−5mA	− 80	28	−1.5	− 4 A										102		
★	〃 229	〃	〃	〃	−100	−40	− 5 A	50 W (Tc=25°C)	91	−5mA	−100	28	−1.5	− 4 A										102		
★	〃 230	〃	〃	〃	−120	−50	− 5 A	50 W (Tc=25°C)	91	−5mA	−120	28	−1.5	− 4 A										102		
★	〃 231	東芝	SW	Ge. D	−120	−120S	− 6 A	25 W (Tc=25°C)	75	−5mA	−120	50	−1.5	− 5 A										102		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB232	松下	PA	Ge. D	−130	−130S	−6A	54 W (Tc=25°C)	90	−220	−14	60	−1	−200										102	
★	〃 233	〃	〃	〃	−130	−130S	−6A	54 W (Tc=25°C)	90	−220	−14	150	−1	−200										102	
★	〃 234	〃	SW	〃	−180	−180S	−6A	54 W (Tc=25°C)	90	−220	−14	25	−1	−6A										102	
★	〃 235	東芝	〃	Ge. A	−80	−80S	−15A	60 W (Tc=25°C)	85	−1.2mA	−12	60	−2	−5A	−6	0.5A					0.3			109	
★	〃 236	〃	〃	〃	−60	−60S	−15A	60 W (Tc=25°C)	85	−1.2mA	−12	60	−2	−5A	−6	0.5A					0.3			109	
★	〃 237	〃	〃	〃	−36	−36S	−15A	60 W (Tc=25°C)	85	−1.2mA	−12	60	−2	−5A	−6	0.5A					0.3			109	
★	〃 238	日電	PA	〃	−40	−30	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−100	−40	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 239	〃	SW	〃	−80	−45	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−100	−80	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 239A	〃	〃	〃	−100	−50	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−200	−100	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 240	〃	PA	〃	−40	−30	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−200	−40	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 240A	〃	〃	〃	−60	−40	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−200	−60	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 241	〃	SW	〃	−80	−45	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−200	−80	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 241A	〃	〃	〃	−100	−50	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−200	−100	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 242	〃	PA	〃	−30	−20R	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−30	40	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 242A	〃	〃	〃	−60	−20R	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−60	40	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 243	〃	〃	〃	−30	−20R	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−30	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 243A	〃	〃	〃	−60	−30R	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−60	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 244	〃	SW	〃	−80	−40R	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−80	40	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 245	〃	〃	〃	−80	−40R	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−80	60	−1	−0.3A	−1	200					0.5			83	
★	〃 246	〃	PA	〃	−40	−25	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−500	−40	60	−1.5	−2A	−1.5	200					>0.2			102	
★	〃 247	〃	SW	〃	−60	−35	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−500	−60	60	−1.5	−2A	−1.5	200					>0.2			102	
★	〃 248	〃	PA	〃	−40	−25	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−40	60	−1.5	−2A	−1.5	200					>0.2			102	
★	〃 248A	〃	〃	〃	−60	−35	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−60	60	−1.5	−2A	−1.5	200					>0.2			102	
★	〃 249	〃	SW	〃	−80	−40	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−80	60	−1.5	−2A	−2	200					>0.2			102	
★	〃 250	〃	PA	〃	−30	−20R	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−30	40	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 250A	〃	〃	〃	−60	−40R	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−60	40	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 251	〃	〃	〃	−30	−20R	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−30	60	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 251A	〃	〃	〃	−60	−40R	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−60	60	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 252	〃	SW	〃	−80	−50R	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−80	40	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 252A	〃	〃	〃	−120	−80R	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−120	40	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB253	日電	SW	Ge. A	−80	−50R	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−80	60	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 253A	〃	〃	〃	−120	−80R	−5A	54 W (Tc=25°C)	90	−5mA	−120	60	−1.5	−2A	−2	200					0.35			102	
★	〃 254	三洋	PA	〃	−35	−35R	−1A	12 W (Tc=25°C)	85	−200	−25	100	−1.5	−200	−1.5	200					0.7			101	
★	〃 255	〃	〃	〃	−35	−35R	−1A	4.8 W (Tc=25°C)	85	−500	−25	50	−1.5	−200	−1.5	200					0.4			101	
★	〃 256	〃	〃	〃	−25	−25R	−1A	12 W (Tc=25°C)	85	−200	−25	100	−1.5	−200	−1.5	200					0.7			101	
★	〃 257	東芝	LN	〃	−18		−5	60	75	−3	−12				−6	1	125	2500	5	4.5	NF = 5 dB (V_{CE}= −3V, I_E=0.5mA)			12 A	
★	〃 258	〃	PA	Ge. D	−120	−115S	−15A	60 W (Tc=25°C)	75	−3.5mA	−12	60	−1.5	−15A	−6	500					1.5			109	
★	〃 259	〃	〃	〃	−80	−75S	−15A	60 W (Tc=25°C)	75	−3.5mA	−12	60	−1.5	−15A	−6	500					1.5			109	
★	〃 260	〃	〃	〃	−50	−45S	−15A	60 W (Tc=25°C)	75	−3.5mA	−12	60	−1.5	−15A	−6	500					1.5			109	
★	〃 261	富士通	AF	Ge. A	−20	−15R	−30	65	85	−12	−12				−6	1	45	2000	6	20	2.5			4	
★	〃 262	〃	PA	〃	−20	−15R	−30	65	85	−12	−12	60	−1.5	−30	−6	115	90	3000	6	30	3			4	2SD162とコンプリ
★	〃 263	〃	〃	〃	−20	−18R	−150	200	85	−14	−12	65	−1	−150	−6	1	60	1650	4.3	19	1.5			12 A	
★	〃 264	日電	LN	〃	−30	−20R	−50	100	75	−5	−6				−1.5	0.5	70	57*	4*	1.5*	NF = 3 dB (V_{CE}=−1.5V, I_E=0.5mA)			19 A	
★	〃 265	東芝	SW	〃	−40	−30S	−100	170	75	−10	−12	62	−1	−100	−6	1		t_r=2.5μs, t_f=1.4μs t_s=1.4μs			1.3	30	140	84 A	
★	〃 266	富士ゼネ	AF	〃	−25		−150	150	85	−10	−12				−6	1	67	1800	3.7	23				12 A	
★	〃 267	〃	PA	〃	−25		−150	150	85	−10	−12	70	−1	−150										12 A	
★	〃 268	三菱	〃	〃	−30	−30R	−150	250	85	−14	−25	75	−1	−150										71 A	
★	〃 269	富士ゼネ	LN	〃	−25		−150	150	85	−10	−15				−6	1	67	2000	4	23	NF = 4 dB (V_{CE}= −2V, I_E=0.5mA)			12 A	
★	〃 270	三洋	AF	〃	−12			150	85	−15	−6				−6	1	80	3000	8	35				12 A	
★	〃 271	〃	PA	〃	−25	−20R	−500	720 (Tc=25°C)	85	−60	−12	80	−1.5	−0.1A	−1.5	100					0.5			12 A	
★	〃 272	〃	〃	〃	−25	−20R	−500	720 (Tc=25°C)	85	−60	−12	100	−6	−0.1A	−1.5	100					0.8			12 A	
★	〃 273	〃	〃	〃	−35	−35R	−500	720 (Tc=25°C)	85	−60	−12	100	−6	−0.1A	−1.5	100					0.8			12 A	
★	〃 274	日立	〃	Ge. D	−80	−80S	−6A	50 W (Tc=25°C)	91	−5mA	−80	30	−1.5	−4A	−1.5	500					1		3.5	102	
★	〃 275	〃	SW	〃	−120	−120S	−6A	50 W (Tc=25°C)	91	−5mA	−120	40	−1.5	−4A	−1.5	500					1		3.5	102	
★	〃 276	〃	〃	〃	−120	−120S	−10A	50 W (Tc=25°C)	91	−5mA	−120	35	−1.2	−10A	−1.5	500					1		3.5	102	
★	〃 277	松下	LN	Ge. A	−15		−5	80	75	−12	−2				−6	1	100	2800	3.8	35	NF = 5 dB			20	
★	〃 278	〃	AF	Si. A	−25		−50	250	150	−0.1	−10				−6	1	28	1300	1.8	13	1			16	
★	〃 279	〃	〃	〃	−25		−50	250	150	−0.1	−10				−6	1	50	2100	2.4	17	1			16	
★	〃 280	〃	〃	〃	−32		−250	300	150	−0.1	−10	24	−2	−30	−6	1	25	800	1.1	10	1.5*			16	
★	〃 281	〃	〃	〃	−60		−250	300	150	−0.1	−10	24	−2	−30	−6	1	40	1400	1.7	18	1.5*			16	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	電気的特性 (T_a = 25°C) 直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB282	松下	SW	Ge. A	−80	−60X	−6A	30 W (Tc=25°C)	90	−100	−0.5	21	−1	−6A	−6	1A					0.25	160		102	
★	〃 283	〃	〃	〃	−60	−48X	−6A	30 W (Tc=25°C)	90	−100	−0.5	53	−1	−6A	−6	1A					0.25	160		102	
★	〃 284	〃	〃	〃	−60	−48X	−6A	30 W (Tc=25°C)	90	−100	−0.5	30	−1	−6A	−6	1A					0.25	160		102	
★	〃 285	〃	〃	〃	−80	−60X	−6A	30 W (Tc=25°C)	90	−100	−0.5	36	−1	−6A	−6	1A					0.25	160		102	
★	〃 286	〃	〃	Ge. D	−80	−80S	−6A	43 W (Tc=25°C)	90	−220	−14	17	−1	−6A										102	
★	〃 287	〃	〃	〃	−80	−80S	−6A	43 W (Tc=25°C)	90	−220	−14	36	−1	−6A										102	
★	〃 288	〃	〃	Ge. A	−32	−32S	−125	125	75	−10	−10	50	−0.7	−125										12A	
★	〃 289	〃	〃	〃	−60	−60S	−125	125	75	−10	−10	50	−0.7	−125										12A	
★	〃 290	東芝	LN	〃	−18		−40	65	75	−4	−12				−3	0.5	110	3500	6	20	5	9.5		84A	
★	〃 291	〃	AF	〃	−30	−25R	−150	150	75	−10	−12	70	−1	−50	−6	1	100	4200	6	30	1	35		84A	
★	〃 292	〃	PA	〃	−30	−25R	−150	150	75	−10	−12	80	−1	−50	−6	1	100	4200	6	30	1	35		84A	
★	〃 292A	〃	〃	〃	−60	−60R	−150	150	75	−10	−12	80	−1	−50										84A	
★	〃 293	富士ゼネ	〃	〃	−18	−13R	−250	150	85	−10	−12	70	−1	−150										12B	
★	〃 294	〃	AF	〃	−18		−250	150	85	−10	−12				−4	1	36	1000	2.9	18				12B	
★	〃 295	富士通	SW	〃	−100	−65R	−5A	40 W (Tc=25°C)	85	−3mA	−100	70	−1	−1A	−1	1A					f_{oe}= 4.5kHz			102	
★	〃 296	東芝	〃	Ge. D	−130	−130S	−10A	35 W (Tc=25°C)	75	−1mA	−50	35	−1.5	−10A										102	
★	〃 297	沖																							
★	〃 298	〃																							
★	〃 299	富士ゼネ	SW	Ge. A	−30	−15R	−150	150	85	−10	−12	65	−1	−150										12B	
★	〃 300	東芝	PA	Ge. D	−100	−100R	−10A	35 W (Tc=25°C)	75	−330	−12	60	−1.5	−5A										102	
★	〃 301	〃	〃	〃	−60	−60R	−10A	35 W (Tc=25°C)	75	−330	−12	60	−1.5	−5A										102	
★	〃 302	日立	LN	Ge. A	−10		−2	40	85	−6	−10				−4	0.5	80	4500	4	26	NF = 4dB (f = 1kHz)			12B	
★	〃 303	三洋	LN. AF	〃	−25		−20	100	75	−15	−15				−2	0.5	180	12KΩ	30	50	NF = 3.5dB (V_{CE} = −6V, I_E = 1mA)			12B	
★	〃 304	富士通	SW	〃	−30		−500	225	70	−15	−30	70	−1	−50										84B	
★	〃 304A	〃	〃	〃	−45	−30R	−500	225	70	−10	−35	70	−1	−50										84B	
★	〃 305	〃																							
★	〃 306	東芝	SW	Ge. A	−105	−105X	−20	75	75	−10	−105	60	−0.35	−2										84A	
★	〃 307																								
★	〃 308																								
★	〃 309	松下	PA	Ge. DB	−75	−75S	−8A	43 W (Tc=25°C)	90	−200	−0.5	62	V_{CB}= 0V	I_E= 1A	−4	1A					f_{oe}= 17kHz			102	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB310	松下	SW	Ge. DB	−140	−140S	−8A	43 W (Tc=25°C)	90	−220	−0.5	62	V_{CB}=0V	I_E=1 A	−4	1 A					f_{ae}=17kHz			102	
★	〃 311	〃	〃	〃	−180	−180S	−10A	50 W (Tc=25°C)	90	−220	−0.5	62	V_{CB}=0V	I_E=1 A	−4	1 A					f_{ae}=17kHz			102	
★	〃 312	〃	〃	〃	−140	−140S	−8A	43 W (Tc=25°C)	90	−220	−0.5	27	V_{CB}=0V	−8A										102	
★	〃 313	〃	〃	〃	−180	−180S	−10A	43 W (Tc=25°C)	90	−220	−0.5	27	V_{CB}=0V	−8A										102	
★	〃 314	沖	PA	Ge. A	−30	−25R	−500	3 W	80	−100	−30	45	−2	−200										95	
★	〃 315	三菱	AF	〃	−16		−300	150	85	−14	−12				−3	1	50	1100	1.5	20				12 A	
★	〃 316	〃	PA	〃	−16	−16S	−300	150	85	−14	−12	60	−1	−150										12 A	
★	〃 317	〃	〃	〃	−16	−16S	−300	250	85	−14	−12	60	−1	−150										71 A	
★	〃 318	富士通	〃	Ge. D	−60	−32	−5A	50 W (Tc=25°C)	100	−1mA	−40	100	−2	−1A	−5	500					2 *			102	
★	〃 319	〃	SW	〃	−100	−40	−5A	50 W (Tc=25°C)	100	−1mA	−40	100	−2	−1A	−5	500					3 *			102	
★	〃 320	〃	〃	〃	−100	−40	−5A	50 W (Tc=25°C)	100	−1mA	−40	100	−2	−1A	−5	500	t_r=1.6μs, t_s=1.3μs	t_f=1μs			2 *			102	
★	〃 321	東芝	LN	Ge. A	−12		−50	40	75	−4	−12				−1.5	0.5	100	4000	6	20	NF=3dB (V_{CE}=−3V, I_E=0.5mA)			1	
★	〃 322	〃	AF	〃	−12		−50	40	75	−4	−12				−1.5	0.5	50	3000	5	19				1	
★	〃 323	〃	〃	〃	−12		−50	40	75	−4	−12				−1.5	0.5	100	4000	6	20				1	
★	〃 324	松下	PA	〃	−32		−1A	200	90	−10	−10	53	V_{CB}=0V	−0.3A	−2	10					f_{ae}=10kHz			12B	
★	〃 325	富士通	SW	〃	−120	−100R	−0.6A	1.8 W (Tc=25°C)	85	−20	−5	50	−2	−50										93	
★	〃 326	日電	PA	〃	−30	−25R	−500	225	85	−10	−30	65	−1	−20	−5	1					3			84 A	
★	〃 327	〃	〃	〃	−30	−25R	−500	225	85	−10	−30	110	−1	−20	−5	1					3.3			84 A	
★	〃 328	〃	〃	〃	−25	−20R	−200	150	85	−10	−15	70	−1	−20	−6	1					2			19 A	
★	〃 329	〃	〃	〃	−25	−20R	−200	150	85	−10	−15	100	−1	−20	−6	1					2			19 A	
★	〃 330	〃	SW	〃	−110	−110X	−150	225	85	−20	−50	35	−1	−20	−5	1					0.5			84 A	
★	〃 331	日立	〃	〃	−40	−40S	−15A	80 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−40	70	−2	−5A										109	
★	〃 332	〃	〃	〃	−60	−50S	−15A	80 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−60	60	−2	−5A										109	
★	〃 333	〃	〃	〃	−80	−70S	−15A	80 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−80	60	−2	−5A										109	
★	〃 334	〃	〃	〃	−100	−60S	−15A	80 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−100	40	−2	−5A										109	
★	〃 335	松下	AF	〃	−20		−60	83	75	−10	−10	36~110	−1	I_B=−250μA	−6	1	70	2800	2.6	10				4	
★	〃 336	〃	PA	〃	−20	−20S	−60	83	75	−10	−10	80	−1	−60										4	
★	〃 337	日立	〃	〃	−40	−30R	−7A	30 W (Tc≦55°C)	100	−1mA	−30	90	−2	−1A	−2	1 A					0.3			102	
★	〃 338	〃	〃	〃	−60	−45S	−7A	50 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−30	75	−4	−1A										102	
★	〃 339	〃	〃	〃	−80	−35	−10A	50 W (Tc=25°C)	90	−250	−30	75	−4	−1A	−4	1 A					0.25			102	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB340	日立	PA. SW	Ge. A	−100	−40	−10A	50 W (Tc=25°C)	90	−250	−30	35	−1	−8A	−4	1 A					0.25			102	
★	〃 341	〃	〃	〃	−120	−50	−10A	50 W (Tc=25°C)	90	−250	−30	35	−1	−8A										102	
★	〃 342	三洋	〃	Ge. D	−120		−6A	30 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−120	50	−1.5	−5A	−1.5	500					1.5			102	
★	〃 343	〃	〃	〃	−150		−6A	30 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−150	50	−1.5	−5A	−1.5	500					1.5			102	
★	〃 344																								
★	〃 345	松下	AF	Ge. A	−32		−100	165	85	−10	−10				−5	2	90	1700	6.5	80	f_{oe}= 17kHz			12 B	
★	〃 346	〃	〃	〃	−32		−100	165	85	−10	−10				−5	2	120	2400	8	100	f_{oe}= 17kHz			12 B	
★	〃 347	〃	LN	〃	−32		−100	165	85	−10	−10				−5	2	90	1700	6.5	80	f_{oe}= 17kHz	NF = 3dB (I_E= 0.5mA)		12 B	
★	〃 348	〃	〃	〃	−32		−100	165	75	−10	−10				−5	2	120	2400	8	100	f_{oe}= 17kHz	NF = 3dB (I_E= 0.5mA)		12 B	
★	〃 349	三洋	AF	〃	−20		−10	50	75	−20	−10	150	−1.5	−10										12 A	
★	〃 350	〃	PA	〃	−25		−50	50	75	−20	−10	100	−1.5	−30										12 A	
★	〃 351	富士通	SW	〃	−40	−40S	−15A	70 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−40	70	−2	−5A										109	
★	〃 352	〃	〃	〃	−60	−50S	−15A	70 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−60	70	−2	−5A										109	
★	〃 353	〃	〃	〃	−80	−70S	−15A	70 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−80	70	−2	−5A										109	
★	〃 354	〃	〃	〃	−100	−80S	−15A	70 W (Tc=25°C)	100	−4mA	−100	70	−2	−5A										109	
★	〃 355	三菱	PA	〃	−25	−25S	−1A	4 W (Tc=25°C)	85	−100	−12	60	−1.5	−0.5A										101	
★	〃 356	〃	〃	〃	−80	−80S	−1A	4 W (Tc=25°C)	85	−50	−50	50	−1.5	−0.5A										101	
★	〃 357	〃	〃	〃	−100	−100S	−1A	3 W (Tc=25°C)	85	−50	−50	40	−1.5	−0.5A										101	
★	〃 358	〃	〃	Ge. D	−80	−80S	−6A	50 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−80	30	−1.5	−4A	1.5	200					2			102	
★	〃 359	〃	SW	〃	−120	−120S	−10A	50 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−80	25	−1.5	−4A	1.5	200								102	
★	〃 360	〃	〃	〃	−180	−180S	−10A	50 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−80	30	−1.5	−4A	1.5	200					2			102	
★	〃 361	日立	PA	Ge. DB	−80	−40	−5A	40 W (Tc=25°C)	100	−500	−40	110	−2	−1A	−5	0.7A					f_{oe}= 50kHz			102	
★	〃 362	〃	〃	〃	−100	−40	−7A	50 W (Tc=25°C)	90	−500	−30	75	−2	−5A	−5	0.7A					f_{oe}= 50kHz			102	
★	〃 363	日電	SW	Ge. D	−140	−140S	−8A	43 W (Tc=25°C)	90	−10mA	−140	50	−1.5	−5A										102	
★	〃 364	東芝	PA	Ge. A	−20	−20R	−400	150	75	−14	−20	60~150	−0.5	−100	−6	1					1			12 A	2SD104 とコンプリ
★	〃 365	〃	〃	〃	−20	−20R	−400	150	75	−14	−20	35~90	−0.5	−100	−6	1					1			12 A	2SD105 とコンプリ
★	〃 366	〃	SW	Ge. D	−140	−140S	−8A	43 W (Tc=25°C)	90	−330	−12	50	−1.5	−5A										102	
★	〃 367	日立	PA	Ge. A	−25	−25S	−1A	6.6 W (Tc=25°C)	85	−100	−12	90	−1.5	−0.5A										100	
★	〃 368	〃	〃	〃	−45	−45S	−1A	6.6 W (Tc=25°C)	85	−100	−12	90	−1.5	−0.5A										100	
★	〃 369																								

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB370	日立	PA	Ge. A	−25	−25S	−500	200	85	−20	−12	150	−1	−150	−6	1	110							12A	2SD170とコンプリ
★	〃 370A	〃	〃	〃	−32	−32S	−500	200	85	−20	−12	150	−1	−150	−6	1	110							12A	2SD170Aとコンプリ
★	〃 371	松下	〃	〃	−32	−32S	−200	165	75	−15	−10	>90	V_{CB}=0V	−1A	−2	10					f_{ae}>10kHz			12B	
★	〃 372	三洋	〃	〃	−25	−25R	−1A	1.5W (Tc=25°C)	85	−50	−20													84B	
★	〃 373	〃	〃	〃	−25	−25R	−1A	1.5W (Tc=25°C)	85	−50	−20	150	−1.5	−200	−1.5	200						0.7		84B	
★	〃 374	〃	〃	〃	−60	−60R	−1A	1.5W (Tc=25°C)	85	−50	−20	150	−1.5	−200										84B	
★	〃 375	〃	SW	Ge. D	−150	−150R	−9A	30W (Tc=25°C)	85	−5mA	−150	50	−1.5	−8A	−1.5	500						1.5		102	
★	〃 376	松下	PA	Ge. A	−20	−20S	−300	225	75	−20	−12	50	−0.5	−300										17	
★	〃 377	ソニー	LN	〃	−32	−30R	−150	270	85	−10	−32				−6	0.5	134	53*	5*	0.3*	NF = 2dB (f= 1kHz)			84A	
★	〃 378	〃	AF. PA	〃	−18	−16R	−150	180	65	−10	−18	42	−1	−20	−6	1	34	27*	3.5*	0.5*	2.5	25		84A	
★	〃 378A	〃	〃	〃	−23	−20R	−300	270	85	−10	−23	42	−1	−20	−6	1	34	27*	3.5*	0.5*	2.5	25		84A	
★	〃 378B	〃	〃	〃	−23	−20R	−500	270	85	−10	−23	42	−1	−20	−6	1	34	27*	3.5*	0.5*	2.5	25		84A	
★	〃 379	〃	〃	〃	−18	−16R	−150	180	65	−10	−18	84	−1	−20	−6	1	68	27*	5*	0.5*	3	25		84A	
★	〃 379A	〃	〃	〃	−23	−20R	−300	270	85	−10	−23	84	−1	−20	−6	1	68	27*	5*	0.5*	3	25		84A	
★	〃 379B	〃	〃	〃	−23	−20R	−500	270	85	−10	−23	84	−1	−20	−6	1	68	27*	5*	0.5*	3	25		84A	
★	〃 380	〃	〃	〃	−18	−16R	−150	180	65	−10	−18	169	−1	−20	−6	1	136	27*	5*	0.3*	3.5	25		84A	
★	〃 380A	〃	〃	〃	−23	−20R	−300	270	85	−10	−23	169	−1	−20	−6	1	136	27*	5*	0.3*	3.5	25		84A	
★	〃 381	〃	〃	〃	−32	−30R	−300	270	85	−10	−32	42	−1	−20	−6	1	34	27*	3.6*	0.5*	2.5	25		84A	
★	〃 382	〃	〃	〃	−32	−30R	−300	270	85	−10	−32	84	−1	−20	−6	1	68	27*	5*	0.5*	3	25		84A	
★	〃 383	〃	PA	〃	−32	−30R	−500	270	85	−10	−32	84	−1	−20	−6	1					3	25		84A	
★	〃 384	富士ゼネ	AF	〃	−20		−30	80	85	−10	−12				−6	1	60	1600	3.5	2.3				12A	
★	〃 385	〃	PA	〃	−20	−15	−30	80	85	−10	−12	50	−1	−50										12A	
★	〃 386	三菱	SW	〃	−30		−300	150	85	−10		80	−0.5	−50										12A	
★	〃 387	日立	AF	〃	−12		−20	30	85	−10	−12				−0.5	0.25	55	6000	4.5	21	4			2B	
★	〃 388	〃																							
★	〃 389	富士通	LN	Ge. A	−12		−10	80	85	−6	−12				−4	0.5	100	8000	15	25	NF = 3dB (f= 1kHz)			12A	
★	〃 390	三洋	PA, SW	Ge. D	−80	−80R	−6A	30W (Tc=25°C)	85	−200	−15	50	−1.5	−3A	−1.5	−500						1.5		102	
★	〃 391	〃	〃	〃	−50	−50R	−6A	30W (Tc=25°C)	85	−5mA	−50	75	−1.5	−3A	−1.5	−500						1.5		102	
★	〃 392	沖	AF, SW	Ge. A	−20	−20S	−200	200	85	−7	−12	75	−0.5	−10	−5	1	90	30*	8*	0.3*				84B	
★	〃 393	〃	〃	〃	−28	−20S	−200	200	85	−7	−12	38	−0.5	−10	−5	1	45	30*	8*	0.3*				84B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SB394	沖	AF. SW	Ge. A	−28	−20S	−200	200	85	−7	−12	75	−0.5	−10	−5	1	90	30*	8*	0.3*				84B	
★	〃 395	〃	〃	〃	−28	−20S	−200	200	85	−7	−12	150	−0.5	−10	−5	1	180	30*	8*	0.3*				84B	
★	〃 396	〃	〃	〃	−40	−40S	−200	150	85	−7	−12	75	−0.5	−10	−5	1	90	30*	8*	0.3*				84B	
★	〃 397	〃	SW	〃	−48	−48S	−80	200	85	−10	−12	45	−0.5	−5										84B	
★	〃 398	〃	〃	〃	−110	−110S	−80	200	85	−15	−100	45	−0.5	−5										84B	
★	〃 399	〃	〃	〃	−110	−110S	−80	200	85	−15	−100	25	−0.5	−20										84B	
★	〃 400	三洋	LN	〃	−20		−40	100	85	−15	−10				−6	1	100	3000	8	35	1	25		12B	
★	〃 401	松下	SW	〃	−40	−32X	−300	240	85	−10	−10	60	−0.5	−300	−5	10					>0.3*			84A	
★	〃 402	〃	〃	〃	−60	−60X	−300	240	85	−10	−10	60	−0.5	−300	−5	10					>0.3*			84A	
★	〃 403	〃	〃	〃	−40	−32X	−300	240	85	−10	−10	100	−0.5	−300	−5	10					>0.7*			84A	
★	〃 404	三洋	〃	〃	−100	−100S	−100	100	85	−20	−100	100	−1.5	−30										84B	
★	〃 405	〃	PA	〃	−25	−25R	−1A	720 (Tc=25°C)	85	−50	−20	100	−1.5	−200							0.7			12A	2SD72とコンプリ
★	〃 406	〃	SW	Ge. D	−200	−100	−10A	37.5W (Tc=25°C)	100	−250	−30	35	−1.5	−8A	−2	500					0.7			102	
★	〃 407	〃	PA	Ge. A	−30	−30R	−7A	30W (Tc=25°C)	85	−500	−30	80	−1.5	−1A	−1.5	500					0.35*			102	
★	〃 408	〃	〃	〃	−25	−25R	−200	300	85	−15	−20	175	−1.5	−100	−1.5	30							<150	12A	
★	〃 409	〃	AF	〃	−12		−50	150	75	−15	−6				−6	1	80	3000	8	35				12A	
★	〃 410	〃	PA. SW	Ge. DB	−135	−135R	−15A	40W (Tc=25°C)	85	−250	−30	50	−1.5	−8A	−1.5	−500					3*			102	
★	〃 411	〃	〃	〃	−200	−200R	−11A	40W (Tc=25°C)	85	−250	−30	40	−1.5	−8A	−1.5	−500					2.5*			102	
★	〃 412	〃	〃	〃	−300	−250R	−11A	40W (Tc=25°C)	85	−250	−30	50	−1.5	−8A										102	
★	〃 413	東芝	PA	Ge. D	−60	−60R	−1.5A	12.5W (Tc=25°C)	85	−100	−12	>30	−1	−0.5A										101	
★	〃 414	〃	〃	〃	−32	−32R	−1.5A	12.5W (Tc=25°C)	85	−100	−12	>30	−1	−0.5A										101	
★	〃 415	〃	〃	Ge. A	−32	−32R	−1A	200	85	−14	−12	40~180	0	−0.3A	−1	100					1			12A	
★	〃 416	沖	AF	〃	−25	−25S	−80	150	85	−10	−12	60	−0.5	−10	−5	1	120	45*	45*	0.4*				84B	
★	〃 417	〃	〃	〃	−45	−45S	−80	150	85	−10	−12	60	−0.5	−10	−5	1	120	45*	45*	0.4*				84B	
★	〃 418	〃	〃	〃	−70	−70S	−80	150	85	−10	−12	60	−0.5	−10	−5	1	120	45*	45*	0.4*				84B	
★	〃 419	日立	PA	Ge. DB	−45	−35	−1.5A	6W (Tc=25°C)	100	−250	−12	80	−1.5	−0.5A										100	
★	〃 420	〃	〃	〃	−120	−35	−1.5A	6W (Tc=25°C)	100	−250	−12	100	−1.5	−1A										100	
★	〃 421	東芝	〃	Ge. D	−80	−80R	−600	300	85	−50	−12	70	−1	−150										77	
★	〃 422	〃	AF	Ge. A	−18		−40	60	75	−12	−12				−6	1	50	1500	4	20				12A	
★	〃 423	〃	PA	〃	−30	−25S	−150	150	75	−30	−30	70	−1.5	−50										12A	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB424	東芝	SW	Ge. A	−80	−80R	−3A	30 W (Tc=25°C)	85	−160	−12	60	−1.5	−1A										102		
★	〃 425	〃	PA	〃	−60	−60R	−3A	30 W (Tc=25°C)	85	−160	−12	60	−1.5	−1A										102		
★	〃 426	〃	〃	〃	−32	−32R	−3A	30 W (Tc=25°C)	85	−160	−12	60	−1.5	−1A										102		○
★	〃 427	富士通	SW	〃	−45	−30R	−500	225	70	−15	−45	60	−1	−100	−6	1					1			84B		
★	〃 428	〃	PA	〃	−45	−30R	−500	225	70	−15	−45	90	−1	−100	−6	1					1			84B		
★	〃 429	日電	〃	〃	−30	−20R	−50	100	85	−16	−30	150	−1	−20										19A		
★	〃 430	松下	〃	Ge. DB	−70	−70R	−20A	80 W (Tc=25°C)	90	−20mA	−70	60	V_{CB}=0V	−4A										109		
★	〃 431	富士通	〃	Ge. A	−32	−32S	−500	200	85	−20	−12	120	−1	−150	−6	1	80	2400	8.9	38	1.2			12A		
★	〃 432	〃	PA. SW	Ge. D	−150	−100R	−5A	50 W (Tc=25°C)	100	−1mA	−40	70	−2	−5A	−5	500					3 *			102		
★	〃 433	〃	SW	Ge. A	−70	−60R	−15A	56 W (Tc=25°C)	85	−4mA	−30	50	−2	−5A										109		
	〃 434	東芝	PA	Si. T	−50	−50	−3A	25 W (Tc=25°C)	150	−10	−30	90	−5	−1A	−5	500					3 *	150		268	2SD234とコンプリ	
	〃 435	〃	〃	〃	−40	−40	−3A	25 W (Tc=25°C)	150	−10	−30	90	−5	−1A	−5	500					3 *	150		268	2SD235とコンプリ	
★	〃 436	沖	AF	Ge. A	−25	−25S	−120	120	85	−10	−12	60	−0.5	−10	−5	1	80	33 *	2.4 *	0.4 *				12A		
★	〃 437	〃	〃	〃	−45	−45S	−120	120	85	−10	−12	60	−0.5	−10	−5	1	80	33 *	2.4 *	0.4 *				12A		
★	〃 438	〃	〃	〃	−70	−70S	−120	120	85	−10	−12	60	−0.5	−10	−5	1	80	33 *	2.4 *	0.4 *				12A		
★	〃 439	東芝	〃	〃	−30	−20R	−150	150	75	−14	−12				−6	1	70~270	4000	8	45	2			12A		
★	〃 440	〃	LN	〃	−30	−20R	−150	150	75	−14	−12				−6	1	70~270	4000	8	45	NF = 3dB (f= 1 kHz)			12A		
★	〃 441	日立	PA	Ge. DB	−160	−45	−6A	40 W (Tc=25°C)	100	−250	−30	50	−1.5	−200										102		
★	〃 442	〃	SW	〃	−160	−60	−6A	40 W (Tc=25°C)	100	−500	−30	50	−1.5	−4A										102		
★	〃 443	〃	AF. LN	Ge. A	−18		−10	100	85	−10	−12				−6	1	150	3900	7.4	53	3			12A		
★	〃 444	〃	〃	〃	−18		−10	100	85	−7	−12				−6	1	160	4300	7.7	59	3			12A		
★	〃 445	富士通	PA	Ge. D	−40	−40R	−1.5A	10 W (Tc=25°C)	85	−200	−12	100	−2	−1A	−5	0.5A					1.5 *			101		
★	〃 446	〃	〃	〃	−60	−60R	−1.5A	10 W (Tc=25°C)	85	−100	−12	100	−2	−1A	−5	0.5A					1.5 *			101		
★	〃 447	〃	PA. SW	〃	−220	−220X	−6A	45 W (Tc=25°C)	90	−500	−50	35	−1	−6A	−5	0.5A					1.5 *			102		
★	〃 448	松下	PA	Ge. A	−32	−30S	−1A	13 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−32	50	−0.5	−1A										100		
★	〃 449	〃	〃	〃	−50	−50S	−3.5A	22.5 W (Tc≦50°C)	100	−3mA	−14	35	V_{CB}=0V	−3A	−2	0.5A					f_{ae} >7kHz			102		
★	〃 450	富士ゼネ	PA	Ge. A	−25	−25S	−500	200	85	−20	−12	120	−1	−150										12A		
★	〃 451	三菱	〃	〃	−25	−25S	−1A	300	85	−30	−12	80	−1	−150										69		
★	〃 452	〃	〃	〃	−25	−25S	−1A	300	85	−30	−12	150	−1	−150										69		○
★	〃 453	〃	PA. SW	〃	−30	−30R	−300	250	85	−12	−25	120	−1	−100	−6	1					>1			69		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SB454	三菱	PA. SW	Ge. A	−80	−80X	−300	250	85	−30	−80	120	−1	−100	−6	1					>1			69	
★	〃 455	〃	〃	〃	−105	−105X	−150	250	85	−30	−105	120	−1	−100	−6	1					>1			69	
★	〃 456	富士通	〃	〃	−80	−50R	−1A	13 W (Tc=25°C)	85	−100	−80	80	−1	−300										83	
★	〃 457	三菱	PA	〃	−20	−20S	−500	150	85	−15	−12	110	−1	−150										12B	
★	〃 457A	〃	〃	〃	−32	−32S	−500	150	85	−15	−12	110	−1	−150										12B	
★	〃 458	〃	〃	〃	−25	−25S	−1A	800	85	−100	−12	65	−1.5	−500										100	
★	〃 458A	〃	〃	〃	−45	−45S	−1A	800	85	−100	−12	65	−1.5	−500										100	
★	〃 458B	〃	〃	〃	−100	−100S	−1A	800	85	−50	−50	65	−1.5	−500										100	
★	〃 459	日立	AF. LN	〃	−30	−18R	−50	120	100	−12	−20	130	−6	−1	−6	1	180	5200	11	78	NF = 4.5dB (−6V, 1mA, 1kHz)			12A	
★	〃 460	〃	〃	〃	−40	−25R	−50	120	100	−6	−20	130	−6	−1	−6	1	180	5200	11	78	NF = 4.5dB (−6V, 1mA, 1kHz)			12A	
★	〃 461	東芝	PA	〃	−35	−30R	−1A	250	85	−14	−12	50~180	−0.5	−500	−1	100					1.2			84A	
★	〃 462	〃	〃	〃	−60	−60R	−2A	6 W (Tc=25°C)	85	−70	−12	80	−1	−0.5A										99	
★	〃 463	〃	〃	〃	−32	−32R	−2A	6 W (Tc=25°C)	85	−70	−12	80	−1	−0.5A										99	
★	〃 464	〃	〃	Ge. D	−100	−100R	−6A	30 W (Tc=25°C)	85	−330	−12	70	−1.5	−1A										102	
★	〃 465	〃	〃	〃	−60	−60R	−6A	30 W (Tc=25°C)	85	−330	−12	70	−1.5	−1A										102	
★	〃 466	富士通	〃	Ge. A	−40	−30S	−500	12 W (Tc=25°C)	90	−500	−30	70	−1.5	−500	−1.5	500					f_{ae} = 13kHz			101	
★	〃 467	〃	〃	〃	−60	−40S	−500	12 W (Tc=25°C)	90	−200	−30	70	−1.5	−500	−1.5	500					f_{ae} = 13kHz			101	
★	〃 468	日立	SW	Ge. DB	−200	−90	−10A	32 W (Tc=25°C)	85	−500	−30	28	−1.5	−4A				t_f = 1.5μs						102	
★	〃 469	東芝																							
★	〃 470	富士通	AF	Ge. A	−25	−18R	−50	80	85	−6	−20				−6	1	160	5000	15	40				12A	
★	〃 471	日立	PA	〃	−60	−45R	−10A	30 W (Tc≦55°C)	100	−500	−30	90	−2	−1A	−2	1					0.3			102	
★	〃 472	〃	〃	〃	−80	−50R	−10A	30 W (Tc≦55°C)	100	−500	−30	90	−2	−1A	−2	1					0.3			102	
★	〃 473	松下	〃	〃	−32	−32S	−1A	4.3 W (Tc=25°C)	90	−15	−10	80	V_{CB} = 0V	−0.5A							f_{ae} = 20kHz			100	
★	〃 474	三洋	〃	〃	−35	−35R	−2A	12 W (Tc=25°C)	85	−200	−25	100	−1.5	−200	−1.5	200					0.7			101	
★	〃 475	松下	〃	〃	−20	−20S	−300	150	85	−20	−12	60	−1	−150										12B	
★	〃 476	〃	〃	〃	−20	−10	−2A	6 W (Tc=25°C)	85	−500	−20	80	−0.5	−2A										84B	
★	〃 477	三菱	PA. SW	〃	−30	−15	−30A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−30	40	−2	−15A										109	
★	〃 478	〃	〃	〃	−60	−30	−30A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−60	40	−2	−15A										109	
★	〃 479	〃	〃	〃	−80	−40	−30A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−80	40	−2	−15A										109	
★	〃 480	〃	〃	〃	−100	−50	−30A	80 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−100	40	−2	−15A										109	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SB481	松下	PA	Ge. A	−32	−32S	−1A	6 W (Tc=25°C)	90	−1mA	−32	50	−0.5	−1 A	−2	100					f_{ae}= 15kHz			100	
★	〃 482	東芝	AF	〃	−35		−50	120	85	−6	−12				−6	1	200	6500	9	56				12A	
★	〃 483	新電元	PA. SW	〃	−80	−60S	−15A	60 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−80	100	−1.5	−10A										102	
★	〃 484	〃	〃	〃	−100	−75S	−15A	60 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−100	100	−1.5	−10A										102	
★	〃 485	〃	〃	〃	−140	−85S	−15A	60 W (Tc=25°C)	85	−5mA	−140	100	−1.5	−10A										102	
★	〃 486	東芝	AF. LN	〃	−25		−50	120	85	−5	−12				−6	1	200	6500	9	56	NF = 3dB (f = 1kHz)			12A	
★	〃 487	富士通	PA	〃	−30	−25S	−500	5 W (Tc=25°C)	85	−20	−12	60	−1	−300										98A	
★	〃 488	〃	〃	〃	−60	−30S	−500	5 W (Tc=25°C)	85	−20	−12	60	−1	−300										98A	
★	〃 489	東芝																							
★	〃 490	〃																							
★	〃 491	三洋			−250		−11A	40W (Tc=25°C)	85			35	−1.5	−8 A							1.0*				
★	〃 492	〃	PA	Ge. A	−25	−25R	−2A	6 W (Tc=25°C)	85	−50	−20	110	−1.5	−200	−1.5	200					0.7			84B	
★	〃 493	松下	PA. SW	〃	−40	−20	−1A	9 W (Tc 25°C)	90	−1mA	−40	70	V_{CB} =0V	3 A										83	
★	〃 494	三菱	PA.	〃	−25	−18	−1A	200	85	−20	−12	55	−1	−150										12A	
★	〃 495	〃	〃	〃	−25	−18	−1A	200	85	−20	−12	110	−1	−150										12A	○
★	〃 496	日立	〃	〃	−25	−18R	−250	300 (Tc≦55°C)	85	−14	−25	90	−1.5	−50	−6	1					2			12C	2SD96 とコンプリ
★	〃 497	富士通	LN	〃	−20	−15R	−30	65	85	−6	−12				−6	1	90	3000	6	30	NF = 3dB (I_E=0.5mA, f=1kHz)			4	
★	〃 498	日電	〃	〃	−25	−20R	−50	100	85	−5	−15				−6	1	170	31	5*	0.25*	NF = 3dB (−6V, 1mA)			19A	
★	〃 499	〃																							
★	〃 500	〃																							
★	〃 501	〃																							
★	〃 502	東芝	PA	Si-EMe	−110	−80	−3 A	25 W (Tc=25°C)	150	−10	−50	80	−5	−500	−10	500					1*	200		99	2SD102 とコンプリ ○
★	〃 503	〃	〃	〃	−70	−50	−3 A	25 W (Tc=25°C)	150	−10	−50	80	−5	−500	−10	500					1*	200		99	2SD103 とコンプリ ○
	〃 504	日電	PA. SW	Si. E	−80	−60	−2A	1 W	175	−1	−60	80	−2	−500	−10	50					35*			84B	2SD78 とコンプリ ○
	〃 505	〃	〃	〃	−80	−60	−2A	15W (Tc=25°C)	175	−1	−60	80	−2	−500	−10	50					35*			97B	2SD79 とコンプリ
	〃 506	〃	〃	Si. EMe	−150	−100	−5A	60W (Tc=25°C)	175	−2mA	−100	70	−5	−1A	−10	300					10*			102	2SD73, 74 とコンプリ ○
	〃 507	三洋	PA	Si. E	−60	−60	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−20	40~320	−2	−1A	−5	500					8*	130		268	
	〃 508	〃	〃	〃	−60	−60	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−20	40~320	−2	−1A	−5	500					8*	130		267	
★	〃 509	〃	〃	〃	−60	−60	−4A	35W (Tc=25°C)	150	−100	−20	40~320	−2	−1A	−5	500					8*			99	2SD315 とコンプリ
★	〃 510	日電	PA. SW	〃	−80	−60	−1 A	800	150	−1	−60	100	−2	−200	−10	50					50*			84B	2SD328 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	r_{bb} h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SB511	三洋	PA	Si. E	−35	−35	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−100	−20	40~320	−2	−1A	−5	500					8*			268		
	〃 512	松下	〃	Si. EMe	−60	−60	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−30	−20	60	−3	−1A	−10	200					$f_{\alpha e}$ 70kHz			268	2SD365 とコンプリ	○
★	〃 513	〃	〃	〃	−60	−60	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−30	−20	60	−3	−1A										267		○
	〃 514	三洋	〃	Si. E	−50	−50	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−20	40~320	−2	−1A	−5	500					8*			268	2SD330 とコンプリ	
	〃 515	〃	〃	〃	−50	−50	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−20	40~320	−2	−1A	−5	500					8*			267	2SD331 とコンプリ	
★	〃 516	日立	〃	Ge.A	−20	−20S	−100	150	85	−25	−12	110	−1.5	−50										12C		
★	〃 517	ソニー																								
★	〃 518	〃	PA	Si. EMe	−90	−90	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−100	−50	50	−2	−1A										102	2SD338 とコンプリ	
★	〃 519	〃	〃	〃	−110	−100	−10A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−50	50	−2	−1A										102	2SD339 とコンプリ	
★	〃 520	〃	〃	〃	−140	−110	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−50	50	−2	−5A	−2	5A					>3*			102	2SD340 とコンプリ	
★	〃 521	〃	〃	〃	−60	−60	−5A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−50	50	−2	−2.5A										268		
★	〃 522	〃	〃	〃	−60	−60	−5A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−50	50	−2	−2.5A										267		
★	〃 523	三菱	〃	Si. EP	−40	−20	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−25	120	−4	−500										180	2SD360 とコンプリ	
	〃 524	〃	〃	〃	−60	−40	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−25	110	−4	−500										180	2SD361 とコンプリ	
★	〃 525	〃	〃	〃	−30	−25	−1A	800	135	−1	−25	150	−1	−500	−6	10					100*			242	2SD355 とコンプリ	
★	〃 526	〃	〃	〃	−90	−80	−800	10W (Tc=25°C)	150	−10	−25	100	−4	−300										180	2SD356 とコンプリ	
	〃 527	〃	〃	〃	−110	−100	−800	10W (Tc=25°C)	150	−10	−25	100	−4	−300										180	2SD357 とコンプリ	
	〃 528	〃	〃	〃	−130	−120	−800	10W (Tc=25°C)	150	−10	−25	100	−4	−300										180	2SD358 とコンプリ	
	〃 529	〃	〃	〃	−40	−20	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−25	110	−4	−500										180	2SD359 とコンプリ	
★	〃 530	東芝	〃	Si. EMe	−110	−110	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−50	80	−5	−1A										102		
★	〃 531	〃	〃	Si.TMe	−100	−100	−6A	50W (Tc=25°C)	150	−100	−50	40~240	−5	−1A	−5	1A					8*	180		102	2SD371 とコンプリ	
★	〃 532	松下	〃	Si.EMe	−80	−80	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−50	100	−4	−1A	−10	500					10*			102	2SD379 とコンプリ	
★	〃 533	〃	〃	Ge. A	−20	−10	−2A	6W (Tc=25°C)	85	−200	−20	150	V_{CB} 0V	I_E 2A	−2	100					1.2*			84B		
★	〃 534	日立	〃	〃	−20	−18	−500	200	85	−25	−12	150	−1	−150										12A		
★	〃 535	〃	〃	〃	−35	−30R	−1A	5W (Tc=25°C)	85	−20	−12	100	−0.5	−500										84B		
	〃 536	日電	〃	SiE	−130	−120	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−120	110	−5	−300	−5	100					40*	35		268	2SD381 とコンプリ	
	〃 537	〃	〃	〃	−130	−120	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−120	110	−5	−300	−5	100					40*	35		267	2SD382 とコンプリ	
★	〃 538	日立	〃	Ge. A	−65	−30	−15A	75W (Tc=25°C)	100	−10mA	−65	100	−2	−10A										102		
★	〃 539	日電	〃	Si.TMe	−130	−120	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−120	75	−5	−2A										102	2SD287 とコンプリ	○
★	〃 540	東芝	〃	Ge. A	−50	−40R	−3A	250	85	−100	−25	100	−2	−3A										84B		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SB541	日電	PA	Si.TMe	−110	−100	−8A	80W (T_c=25°C)	150	−100	−100	80	−5	−1A	−10	200					7 *	320		102	2SD388 とコンプリ	
★	〃 542	三菱	〃	Si.EP	−20	−15	−300	300	125	−1	−20	150	−2	−150	−6	10					150 *			138B	2SD392 とコンプリ	
	〃 543																									
	〃 544	三洋	PA	Si. EP	−25	−25	−1A	900	150	−1	−20	60~560	−2	−50	−10	50					180 *	25		294	2SD400 とコンプリ	
★	〃 545	日電																								
★	〃 546	〃	PA	Si.TMe	−200	−150	−2A	20W (T_c=25°C)	150	−50	−150	90	−10	−400										268	2SD401 とコンプリ	○
★	〃 547	〃	〃	〃	−200	−150	−2A	20W (T_c=25°C)	150	−50	−150	90	−10	−400										267	2SD402 とコンプリ	○
	〃 548	〃	〃	Si.E	−100	−80	−800	10W (T_c=25°C)	150	−1	−80	90	−5	−200	−5	100					70 *	25		225	2SD414 とコンプリ	
	〃 549	〃	〃	〃	−100	−100	−800	10W (T_c=25°C)	150	−1	−80	90	−5	−200	−5	100					70 *	25		225	2SD415 とコンプリ	
	〃 550	〃	PA.SW	Si.EMe	−100	−70	−5A	25W (T_c=25°C)	150	−100	−80	80	−5	−1A	−10	100					10 *			134	2SD284 とコンプリ	
★	〃 551	日立	PA	Si. T	−50	−50	−3A	25W (T_c=25°C)	150	−100	−20	35~200	−4	−1A	−4	500					32 *			153	2SC830 とコンプリ	
	〃 552	東芝	PA	Si.TMe	−220	−180	−15A	150W (T_c=25°C)	150	−100	−150	25~80	−5	−5A	−10	1A					3.5 *	300		102	2SD552 とコンプリ	
	〃 553	〃	SW.PA	Si. T	−70	−50	−7A	40W (T_c=25°C)	150	−30	−70	70~240	−1	−1A	−4	1A	t_{on}=0.2μs, t_f=0.5μs t_{stg}=2.5μs				10 *	250		268	2SD553 とコンプリ	
	〃 554	〃	PA	Si.TMe	−180	−180	−15A	150W (T_c=25°C)	150	−100	−90	40~140	−5	−2A	−5	2A					6 *	450		102	2SD424 とコンプリ	
★	〃 555	〃	〃	〃	−140	−140	−12A	100W (T_c=25°C)	150	−100	−60	40~140	−5	−2A	−5	2A					6 *	330		102	2SD425 とコンプリ	
★	〃 556	〃	〃	〃	−120	−120	−12A	100W (T_c=25°C)	150	−100	−60	40~140	−5	−2A	−5	2A					6 *	330		102	2SD426 とコンプリ	
	〃 557	〃	〃	〃	−120	−120	−8A	80W (T_c=25°C)	150	−100	−60	40~140	−5	−1A	−5	1A					7 *	280		102	2SD427 とコンプリ	
	〃 558	〃	〃	〃	−100	−100	−7A	60W (T_c=25°C)	150	−100	−50	40~140	−5	−1A	−5	1A					7 *	220		102	2SD428 とコンプリ	
	〃 559	三洋	〃	Si.EP	−20	−18	−1.2A	8W (T_c=25°C)	150	−1	−15	60~320	−2	−500	−10	50					150 *	30		296	2SD439 とコンプリ	
	〃 560	〃	〃	〃	−100	−80	−700	900	150	−1	−20	60~560	−5	−50	−10	50					100 *	15		294	2SD438 とコンプリ	
	〃 561	日立	〃	Si. E	−25	−20	−700	500	150	−1	−20	85~240	−1	−150	−1	150					350 *	20		138	2SD467 とコンプリ	
	〃 562	〃	〃	〃	−25	−20	−1A	900	150	−1	−20	85~240	−2	−500	−2	500					350 *	38		251	2SD468 とコンプリ	
★	〃 563	日電	PA.SW	Si.EMe	−80	−70	−3A	25W (T_c=25°C)	150	−100	−70	70	−2	−1A			t_{on}=0.4μs, t_{off}=1.2μs t_{stg}=0.8μs							134	2SD297 とコンプリ	
	〃 564	〃	PA	Si. E	−30	−25	−1A	800	150	−0.1	−30	200	−1	−100	−6	10					110 *	36		278		
★	〃 565	日立	〃	Si. T	−50	−50	−4A	40W (T_c=25°C)	150	−100	−20	100	−4	−1A										267		
★	〃 566	〃	〃	〃	−70	−50	−4A	40W (T_c=25°C)	150	−1	−50	60~200	−4	−1A	−4	500					7 *			268	2SD476 とコンプリ	○
★	〃 567	〃	〃	〃	−200	−150	−2A	30W (T_c=25°C)	150	−1	−120	150	−4	−50										267		
★	〃 568	〃	〃	〃	−200	−150	−2A	30W (T_c=25°C)	150	−1	−120	60~320	−4	−50								30		268	3D478 とコンプリ	
	〃 569	モトローラ	〃	Si.E	−40	−40	−4A	40W (T_c=25°C)	150	−500	−40	6000	−3	−2A										252	2SD479 とコンプリ	
	〃 570	〃	〃	〃	−60	−60	−4A	40W (T_c=25°C)	150	−500	−60	6000	−3	−2A										252	2SD480 とコンプリ	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SB571	モトローラ	PA	Si.E	−80	−80	−4A	40W (T_c=25°C)	150	−500	−80	6000	−3	−2A										252	2SD481 とコンプリ
〃 572	〃	〃	〃	−40	−40	−3A	30W (T_c=25°C)	150	−100	−40	50	−1	−500										252	2SD488 とコンプリ
〃 573	〃	〃	〃	−60	−60	−3A	30W (T_c=25°C)	150	−100	−60	50	−1	−500										252	2SD489 とコンプリ
〃 574	〃	〃	〃	−80	−80	−3A	30W (T_c=25°C)	150	−100	−80	50	−1	−500										252	2SD490 とコンプリ
〃 575	〃	〃	〃	−40	−40	−4A	40W (T_c=25°C)	150	−100	−40	50	−2	−1.5A										252	2SD485 とコンプリ
〃 576	〃	〃	〃	−60	−60	−4A	40W (T_c=25°C)	150	−100	−60	50	−2	−1.5A										252	2SD486 とコンプリ
〃 577	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	40W (T_c=25°C)	150	−100	−80	50	−2	−1.5A										252	2SD487 とコンプリ
〃 578	〃	〃	〃	−70	−60	−10A	90W (T_c=25°C)	150	−1mA	−70	40	−4	−4A										253	2SD491 とコンプリ
〃 579	〃	〃	〃	−60	−40	−5A	75W (T_c=25°C)	150	−100	−60	40	−2	−2.5A										253	2SD493 とコンプリ
〃 580	〃	〃	〃	−80	−60	−5A	75W (T_c=25°C)	150	−100	−80	40	−2	−2.5A										253	2SD494 とコンプリ
〃 581	〃	〃	〃	−100	−80	−5A	75W (T_c=25°C)	150	−100	−100	40	−2	−2.5A										253	2SD495 とコンプリ
〃 582	〃	〃	〃	−60	−60	−8A	75W (T_c=25°C)	150	−500	−60	3000	−4	−4A										253	2SD496 とコンプリ
〃 583	〃	〃	〃	−80	−80	−8A	75W (T_c=25°C)	150	−500	−80	3000	−4	−4A										253	2SD497 とコンプリ
〃 584	〃	〃	〃	−100	−100	−8A	75W (T_c=25°C)	150	−500	−100	3000	−4	−3A										253	2SD498 とコンプリ
〃 585	〃	〃	〃	−60	−60	−8A	100W (T_c=25°C)	200	−500	−60	3000	−3	−4A										102	2SD502 とコンプリ
〃 586	〃	〃	〃	−80	−80	−8A	100W (T_c=25°C)	200	−500	−80	3000	−4	−8A										102	2SD503 とコンプリ
〃 587	〃	〃	〃	−60	−60	−12A	150W (T_c=25°C)	200	−500	−50	3000	−3	−6A										102	2SD504 とコンプリ
〃 588	〃	〃	〃	−80	−80	−12A	150W (T_c=25°C)	200	−500	−80	3000	−3	−6A										102	2SD505 とコンプリ
〃 589	〃	〃	〃	−100	−100	−12A	150W (T_c=25°C)	200	−500	−100	3000	−3	−6A										102	2SD506 とコンプリ
★ 〃 590																								
★ 〃 591																								
★ 〃 592	日立																							
★ 〃 593	〃																							
★ 〃 594	〃																							
〃 595	東芝	PA	Si. T	−100	−100	−5A	40W (T_c=25°C)	150	−100	−100	40~240	−5	−1A	−5	1 A					5 *	270		268	2SD525 とコンプリ
〃 596	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	30W (T_c=25°C)	150	−30	−80	40~240	−5	−500							>3 *	130		268	2SD526 とコンプリ
★ 〃 597	〃																							
〃 598	三洋	PA	Si. EP	−25	−25	−1 A	600	150	−1	−20	60~320	−2	−50	−10	50					180 *	15		138	2SD545 とコンプリ
〃 599	日電	〃	Si.TMe	−200	−200	−2 A	30W (T_c=25°C)	150	−10	−200	80	−5	−300										134	2SD554 とコンプリ
〃 600	〃	〃	Si. T	−200	−200	−10A	200W (T_c=25°C)	150	−50	−200	70	−5	−2 A	−5	200					14 *	450		102	2SD555 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SB601	日電	PA.SW	Si.E ダーリントン	100	−100	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	2000~15000	−2	−3A			t_{on}=0.5μs, t_{stg}=1μs			t_f=1μs				268	2SD560とコンプリ	
★	〃 602	〃																								
	〃 603	日電	SW	Si.T	−500	−500	−500	800	175	−10	−500	>50	−5	−100			t_{on}=1μs, t_{stg}=6μs			t_f=1μs				84B		
★	〃 604	松下	PA	Si.TMe	−70	−70	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−1mA	−70	120	−5	−500										268		
	〃 605	日電	〃	Si.E	−60	−50	−700	800	150	−0.1	−60	200	−1	−100	−6	10					120*	25		278	2SD571とコンプリ	
	〃 606	富士通	SW	Si.EP	−250	−250	−500	800	175	−0.5	−200	70	−10	−10			t_{on}<0.2μs t_{stg}<3.0μs			t_{off}<2.0μs				84C	2SD576とコンプリ	
	〃 607	松下	PA	Ge.A	−30	−30R	−1A	3W (Tc=25°C)	85	−10	−10	60	−0.5	−1A	−2	100					$f_{\alpha e}$ 15kHz			84C		
★	〃 608	日立	〃	Si.T	−180	−140	−2A	30W (Tc=25°C)	150	−1	−120	60~320	−4	−50										268		
★	〃 609	〃	〃	Si.E	−100	−80	−4A	40W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} −100	V_{CE} −80	60~320	−4	−500										153		
★	〃 610	〃																								
★	〃 611	〃	PA	Si.E	−150	−100	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−10	−120	120	−5	−1A										102		○
★	〃 612	〃	〃	〃	−180	−140	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−10	−160	100	−5	−1A										102		○
★	〃 613	〃	〃	〃	−250	−200	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−10	−220	120	−5	−2A										102		
★	〃 614	三菱																								
★	〃 615	〃																								
★	〃 616	日電	PA	Si.E	−100	−80	−5A	60W Tc=25°C	150	−10	−80	80	−5	−1A	−5	100					22*	120		295	2SD586とコンプリ	○
★	〃 617	〃	〃	Si.T	−120	−100	−6A	70W Tc=25°C	150	−50	−100	80	−5	−1A	−5	200					14*	220		295	2SD587とコンプリ	○
★	〃 618	〃	〃	〃	−150	−120	−7A	80W Tc=25°C	150	−50	−120	80	−5	−1A	−5	200					14*	340		295	2SD588とコンプリ	○
	〃 619	松下	〃	Ge.A	−32	−32R	1.3A	300	90	−10	−10	115	−0.5	−300							$f_{\alpha e}$ 15kHz	NF=10dB (f=1kHz)		12A		
	〃 620	〃	〃	Si.EP	−25	−25	−50	250	125	−1	−10	250	−5	−2	−10	1					100*	2.7	70	138		
	〃 621	〃	AF	〃	−30	−25	−1A	750	150	−0.001	−20	160	−10	−500	−5	1		5k*	1	0.09	200*	20		138		○
★	〃 622	サンケン	PA	Si.TMe	−400	−400	−300	800	150	−100	−400	>30	−4	−50	−5	100					10*			84B	2SD593とコンプリ	
★	〃 623	日電																								
	〃 624	〃	AF	Si.E	−30	−25	−700	200	150	−0.1	−30	200	−1	−100	−6	10					160*	17		176	2SD596とコンプリ	
★	〃 625	松下	PA	Si.EMe	−100	−100	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	40~200	−5	−1A	−10	500					7*			102	2SD597とコンプリ	
★	〃 626	〃	〃	〃	−120	−120	−6A	80W (Tc=25°C)	150	−1mA	−70	40~200	−5	−1A	−10	500					6*			102	2SD598とコンプリ	
★	〃 627	〃	〃	Ge.A	−40	−12	−10A	13W (Tc=25°C)	85	−1mA	−40	150	V_{ce} −0.5	−3A										83		
	〃 628	日電	〃	Si.E	−160	−160	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−120	80	−5	−300	−5	100					40*	35		268	2SD608とコンプリ	
★	〃 629	〃																								
★	〃 630	〃	PA	Si.E	−200	−200	−2A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−150	80	−10	−500	−10	500					4*	65		268	2SD610とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SB631	三洋	PA	Si. EP	−100	−100	−1A	8 W (Tc=25°C)	150	−1	−50	60~320	−5	−50	−10	50					110*	30		296	2SD600 とコンプリ	
	〃 632	〃	〃	〃	−25	−25	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−20	60~320	−2	−500	−10	50					100*	45		296	2SD612 とコンプリ	
	〃 633	〃	〃	〃	−100	−85	−6A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	40~320	−5	−1A	−5	1 A					15*	150		268	2SD613 とコンプリ	
★	〃 634	〃	〃	Si.EMe	−120	−100	−7 A	60W (Tc=25°C)	150	−100	−80	40~320	−5	−1 A	−5	1 A					15*			102		
	〃 635	松下	AF	Ge. A	−32		−150	150	85	−12	−10	180	V_{CB} −0.5	−2	−2	3		1.8k	7.5	90	0.7			297		
	〃 636	〃	PA	〃	−32		−150	150	85	−12	−10	90	V_{CB} −0.5	−100	−6	1	NF=3dB (f=1kHz, V_{CB}=−2V, I_E=0.5mA)				0.7			297		
	〃 637	日立	AF	Si. E	−50	−50	−100	300	150	−0.1	−18	160~800	−12	−2	−12	2					200*	1.8		138		
	〃 638	〃	PA	〃	−100	−100	−10A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−100	1000~20000	−3	−5A			t_{on}=2μs, t_{off}=8μs							102	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 639	〃	〃	〃	−100	−100	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−100	1000~20000	−3	−5A			t_{on}=2μs, t_{off}=8μs							102	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 640	松下	〃	Ge. A	−25	−25S	−300	150	85	−20	−12	150	V_{CB} −0.5	−150			NF=15dB (f=1kHz, V_{CB}=−6V, I_E=5mA)							297		
	〃 641	〃	〃	Si. EP	−30	−25	−100	400	135	−1	−20	200	−10	−2	−5	2	150	3 k	3	50	120*	3.5	100	151		
	〃 642	〃	〃	〃	−60	−50	−100	400	135	−1	−20	200	−10	−2	−5	2	150	3 k	3	50	120*	3.5	100	151		
	〃 643	〃	〃	〃	−30	−25	−500	600	135	−0.1	−20	160	−10	−10	−10	50					200*	6	3.5k*	151	2SD638 とコンプリ	
	〃 644	〃	〃	〃	−60	−50	−500	600	135	−0.1	−20	160	−10	−10	−10	50					200*	6	3.5k*	151	2SD639 とコンプリ	
★	〃 645	東芝	〃	Si.TMe	−200	−200	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−100	−100	40~140	−5	−1A	−10	1 A					12*	450		102	2SD665 とコンプリ	
	〃 646	日立	〃	Si. E	−120	−80	−50	900	150	−10	−100	60~320	−5	−10	−5	10					140*	4		251	2SD666 とコンプリ	○
	〃 647	〃	〃	〃	−120	−80	−1A	900	150	−10	−100	60~320	−5	−150	−5	150					140*	20		251	2SD667 とコンプリ	○
	〃 648	〃	〃	〃	−180	−120	−50	1 W	150	−10	−160	60~320	−5	−10	−10	10					140*	4.5		160	2SD668 とコンプリ	○
	〃 649	〃	〃	〃	−180	−120	−1.5A	1 W	150	−10	−160	60~320	−5	−150	−5	150					140*	27		160	2SD669 とコンプリ	○
	〃 650	〃	〃	〃	−100	−100	−15A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−100	1000~20000	−3	−8A			t_{on}=2μs, t_{off}=8μs							102	ダーリントンダンパ内蔵	
★	〃 651																									
★	〃 652	日立																								
★	〃 653	〃	PA	Si. T	−120	−100	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	60~200	−5	−1A										102	2SD673 とコンプリ	○
★	〃 654	〃	〃	〃	−120	−120	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	60~200	−5	−1A										102	2SD674 とコンプリ	○
★	〃 655	〃	〃	〃	−160	−140	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−140	60~200	−5	−1A										102	2SD675 とコンプリ	○
★	〃 656	〃	〃	〃	−160	−160	−12A	125W (Tc=25°C)	150	−1mA	−140	60~200	−5	−1A										102	2SD676 とコンプリ	○
★	〃 657																									
★	〃 658																									
★	〃 659																									
★	〃 660																									

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SB661																									
★	〃 662																									
★	〃 663																									
★	〃 664																									
★	〃 665																									
★	〃 666																									
★	〃 667																									
★	〃 668	松下	PA	Si.EMe	−60	−60	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−200	−60	4000	−3	−500									268	ダーリントン	○
★	〃 669	〃	〃	〃	−70	−70	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−200	−70	4000	−3	−1A									268	ダーリントン	○
★	〃 670																									
★	〃 671	東芝																								
★	〃 672	〃																								
	〃 673	〃	SW	Si.T	−100	−100	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−100	2000～15000	−3	−3A			t_{on}=0.8μs, t_f=2.5μs t_{stg}=2μs						268	ダーリントン 2SD633 とコンプリ	
	〃 674	〃	〃	〃	−80	−80	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	2000～15000	−3	−3A			〃						268	ダーリントン 2SD634 とコンプリ	
	〃 675	〃	〃	〃	−60	−60	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−60	2000～15000	−3	−3A			〃						268	ダーリントン 2SD635 とコンプリ	
	〃 676	〃	SW.PA	Si.E	−100	−80	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−20	−100	>2000	−2	−1A			t_{on}=0.15μs, t_f=0.4μs t_{stg}=0.8μs						268	ダーリントン	
	〃 677	〃	〃	〃	−60	−40	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−20	−60	>2000	−2	−1A			t_{on}=0.3μs, t_f=0.25μs t_{stg}=0.6μs						268	ダーリントン	
	〃 678	〃	PA.SW	〃	−100	−100	−1.5A	800	175	−10	−100	>2000	−2	−100			t_{on}=0.3μs, t_f=0.7μs t_{stg}=2μs						84B	ダーリントン 2SD688 とコンプリ	
	〃 679	〃	〃	〃	−100	−100	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−100	>2000	−2	−100			t_{on}=0.3μs, t_f=0.7μs t_{stg}=2μs						268	ダーリントン 2SD689 とコンプリ	
★	〃 680																									
	〃 681	〃	PA	Si.TMe	−150	−150	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−100	40～140	−5	−1A	−10	1A					13*	300		102	2SD551 とコンプリ	
★	〃 682	三菱	〃	Si.EP	−100	−100	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−30	−100	55～300	−5	−500	−10	500					8*	75		301B	2SD712 とコンプリ	
★	〃 683	〃	〃	〃	−100	−100	−5A	40W (Tc=25°C)	150	−30	−100	55～300	−5	−1A	−10	500					8*	130		301B	2SD713 とコンプリ	
★	〃 684	〃																								
★	〃 685	〃	PA	Si.EP	−110	−110	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−110	2000～24000	−4	−1A	−4	500					30*			341	ダーリントン	
	〃 686	東芝	〃	Si.T	−100	−100	−6A	60W (Tc=25°C)	150	−10	−100	55～160	−5	−1A	−5	1A					10*	270		179	2SD716 とコンプリ	
★	〃 687	〃																								
	〃 688	〃	PA	Si.T	−120	−120	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−10	−120	55～160	−5	−1A	−5	1A					10*	280		179	2SD718 とコンプリ	
★	〃 689	日立	〃	〃	−100	−100	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	50～250	−4	−500										268		
★	〃 690	〃	〃	〃	−100	−80	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	60～240	−5	−1A	−5	500					20*	75		268	2SD726 とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SB691	松下	PA	Si.EMe	−130	−80	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−50	−80	100	−5	−1A	−5	500					7*	190		365	2SD727 とコンプリ	
★	〃 692	〃	〃	〃	−150	−100	−6A	70W (Tc=25°C)	150	−50	−100	100	−5	−1A	−5	500					7*	300		365	2SD728 とコンプリ	
	〃 693	日立	SW.PA	Si.E	−100	−100	−20A	125W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} −1	−80	1000～20000	−3	−10A			t_{on} = 2 μs, t_{off} = 8 μs							102	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 694	〃	〃	〃	−100	−100	−25A	125W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} −1	−80	1000～20000	−3	−12A			t_{on} = 2 μs, t_{off} = 8 μs							102	ダーリントン ダンパ内蔵	
★	〃 695	松下	〃	Si.EMe	−170	−120	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−50	−120	100	−5	−1A	−5	500					7*	350		365	2SD731 とコンプリ	
★	〃 696	三洋	〃	〃	−150	−120	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−80	40～320	−5	−1A	−5	1A					15*			102	2SD732 とコンプリ	
★	〃 697	〃	〃	〃	−160	−140	−12A	100W	150	−100	−80	40～320	−5	−1A	−5	1 A					15*			102	2SD733 とコンプリ	
	〃 698	〃	〃	Si.EP	−25	−20	−700	600	150	−1	−20	60～560	−2	−50	−10	50					250*	13		138	2SD734 とコンプリ	
★	〃 699	日立	〃	Si.T	−160	−120	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−120	35～200	−5	−1A										332	2SD735 とコンプリ	
★	〃 700	〃	〃	〃	−160	−140	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−120	60～200	−5	−1A										332	2SD736 とコンプリ	○
★	〃 701	〃	〃	〃	−160	−160	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−1mA	−140	120	−5	−1A										332		
★	〃 702	〃	〃	〃	−160	−160	−12A	125W (Tc=25°C)	150	−1mA	−140	60～200	−5	−1A										332	2SD738 とコンプリ	○
★	〃 703	日電	PA.SW	Si.E	−100	−80	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−80	100	−5	−500	−5	100					18*	110		268	2SD743 とコンプリ	○
★	〃 704	〃																								
★	〃 705	〃	PA	Si.T	−140	−140	−10A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−140	80	−5	−2A	−5	200					17*	430		340	2SD745 とコンプリ	○
★	〃 706	〃	〃	〃	−180	−180	−10A	200W (Tc=25°C)	150	−50	−180	80	−5	−2A	−5	200					14*	450		265	2SD746 とコンプリ	○
	〃 707	〃	PA.SW	Si.E	−80	−60	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−60	40～200	−1	−3A										268	2SD568 とコンプリ	
	〃 708	〃	〃	〃	−80	−80	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−60	40～200	−1	−3A										268	2SD569 とコンプリ	
	〃 709	松下	AF	Si.EP	−25	−25	−100	200	125	−1	−10	90～650	−10	−2	−10	1					80*	2.7		176	2SD601 とコンプリ	○
	〃 710	〃	〃	〃	−30	−30	−500	200	125	−0.1	−10	160	−10	−150	−10	50					200*	6		176	2SD602 とコンプリ	○
	〃 711	サンケン	PA	〃	−80	−80	−6A	50W (Tc=25°C)	150	−100	−80	1000	−4	−7A										298	ダーリントン	
	〃 712	〃	〃	〃	−100	−100	−6A	50W (Tc=25°C)	150	−100	−100	1000	−4	−7A										298	ダーリントン	
	〃 713	松下	〃	〃	−200	−140	−9A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−140	100	−5	−1A	−5	500					7*	220		365	2SD751 とコンプリ	
★	〃 714	〃	〃	Ge.A	−20		−2A	6 W (Tc=25°C)	85	−500	−20	120	−0.6	−2A	−2	100					1.2*			84C		
	〃 715	日立	〃	Si.E	−100	−100	−50	750	150	−0.5	−80	250～800	−12	−2	−12	5					150*	1.8		251	2SD755 とコンプリ	
	〃 716	〃	〃	〃	−120	−120	−50	750	150	−0.5	−100	250～800	−12	−2	−12	5					150*	1.8		251	2SD756 とコンプリ	○
	〃 717	〃	〃	〃	−160	−160	−50	1.25W	150	−10	−140	60～320	−5	−10	−5	10					140*	5.5		234	2SD757 とコンプリ	
	〃 718	〃	〃	〃	−200	−200	−50	1.25W	150	−10	−160	60～320	−5	−10	−5	10					140*	5.5		234	2SD758 とコンプリ	
★	〃 719	〃	〃	〃	−160	−160	−2A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−140	35～320	−5	−150	−5	150					100*	32		268	2SD759 とコンプリ	
★	〃 720	〃	〃	〃	−200	−200	−2A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−160	35～200	−5	−150	−5	150					100*	32		268	2SD760 とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SB721	日立	PA	Si. E	−25	−20	−700	625	150	−0.1	−20	100~320	−1	−350	−1	150					350*	20		138D	2SD754 とコンプリ	
★	〃 722	〃	〃	Si. T	−160	−160	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−1mA	−140	100	−5	−1A										102		
★	〃 723	〃	〃	〃	−200	−200	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−1mA	−160	35~200	−5	−1A										102	2SD753 とコンプリ	
	〃 724	松下	〃	Si.EMe	−60	−60	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−30	−20	80	−3	−1A										268		
	〃 725	〃	AF	Si. EP	−60	−60	−100	400	150	−1	−10	250	−5	−2	−10	1	120	3.4k	1.5	13	80*	2.7		138	2SD767 とコンプリ	
	〃 726	〃	〃	〃	−80	−80	−100	400	150	−0.1	−10	360	−5	−2	−5	1	400	1.6k	1.5	12				138		
	〃 727	日立	SW	Si. E	−120	−120	−6A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−120	1000~20000	−3	−3A		t_{on} = 1 μs, t_{off} = 3 μs								268	ダーリントン ダンパ内蔵	
★	〃 728																									
★	〃 729																									
★	〃 730	日電																								
	〃 731	〃	PA. SW	Si. E	−60	−50	−1A	10W (Tc=25°C)	150	−0.1	−50	250	−2	−100	−2	10					75*	25		225		
	〃 732																									
	〃 733	日電	PA	Si. E	−20	−16	−2A	1 W	150	−0.1	−16	300	−2	−100	−2	10					>50*	27		278	2SD773 とコンプリ	
	〃 734	〃	〃	〃	−60	−50	−1A	1 W	150	−0.1	−50	250	−2	−100	−2	10					80*	23		278	2SD774 とコンプリ	
★	〃 735	〃																								
	〃 736	〃	PA	Si. E	−60	−60	−300	200	150	−0.1	−50	200	−1	−50	−6	10					100*	13		176	2SD780 とコンプリ	○
	〃 737	ローム	AF. LN	Si. EP	−50	−40	−300	250	125	−0.5	−30	120~560	−6	−10	−6	10	V_{NO}<150mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				100*		2	138	2SD786 とコンプリ	
	〃 738	日立	PA	Si. E	−20	−16	−2A	900	150	−2	−16	100~320	−2	−100	−2	10					80*	50		251	2SD787 とコンプリ	
	〃 739	〃	〃	〃	−20	−20	−2A	900	150	−2	−16	100~320	−2	−100	−2	10					80*	50		251	2SD788 とコンプリ	
	〃 740	〃	〃	〃	−70	−50	−1A	900	150	−1	−55	100~320	−2	−100	−2	10					150*	35		251	2SD789 とコンプリ	
★	〃 741	〃	〃	〃	−70	−70	−1A	900	150	−1	−55	200	−2	−100	−2	10					65*	35		251	2SD790 とコンプリ	
★	〃 742	日電	〃	〃	−20	−16	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−0.1	−16	300	−2	−100										225		
★	〃 743	〃	PA. SW	〃	−40	−30	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−30	100	−5	−1A	−5	100					55*	75		225	2SD793 とコンプリ	
	〃 744	〃	〃	〃	−70	−45	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−45	100	−5	−500	−5	100					45*	60		225	2SD794 とコンプリ	○
	〃 745	松下	LN	Si. EP	−35	−35	−50	400	150	−0.1	−10	490	−5	−2	−5	1	500	3.5k	1.4	12	NF=0.5dB (−10V, −1mA, f=1kHz)			151	2SD661 とコンプリ	○
★	〃 746	日立	PA	〃	−25	−20	−500	400	150	−0.2	−18	120	−1	−50	−1	50					260*	4.6	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138		
	〃 747	松下	〃	〃	−80	−80	−5A	50W (Tc=25°C)	150	−50	−80	90	−5	−1A	−5	500					7*	190		268	2SD812 とコンプリ	
★	〃 748	日立	〃	Si. T	−120	−100	−6A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	100	−5	−1A										332		○
★	〃 749	〃	〃	〃	−120	−120	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	100	−5	−1A										332		○
	〃 750	松下	PA. SW	Si. EP	−60	−60	−2A	35W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	1000~10000	−4	−1A			t_{on}=0.2μs, t_{off}=2 μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵	○

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
	2SB751	松下	PA.SW	Si.EP	−60	−60	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−200	−60	1000～10000	−3	−3A			t_{on}=0.2μs, t_{off}=2μs							268	ダーリントンダンパ内蔵	○
★	〃 752	東芝																								
	〃 753	〃	SW.PA	Si.T	−100	−80	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−5	−100	70～240	−1	−1A	−4	1A	t_{on}=0.4μs, t_f=0.5μs t_{stg}=2.5μs				10 *	250		268	2SD843とコンプリ	
	〃 754	〃	〃	〃	−50	−50	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−10	−50	70～240	−1	−1A	−5	1A					10 *	300		179	2SD844とコンプリ	
	〃 755	〃	PA	〃	−150	−150	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−150	55～160	−5	−1A	−10	1A					20 *	450		125	2SD845とコンプリ	
★	〃 756	〃																								
	〃 757	富士電機	SW.PA	Si.EP	−40	−40	−15A	80W (Tc=25°C)	150	−10	−40	＞40	−2	−5A			t_{on}＜1μs, t_f＜1μs t_{stg}＜2μs							211	2SD847とコンプリ	
	〃 758	日電	PA	Si.T	−120	−120	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−50	−110	80	−5	−1A										295		○
★	〃 759	松下	AF.RF	Si.EP	−25	−25	−50	250	125	−1	−10	90～700	−5	−2										276		○
★	〃 760	〃	PA	〃	−60	−60	−1A	30W (Tc=25°C)	150	−200	−60	120	−4	−200										268	2SD855とコンプリ	○
	〃 761	〃	〃	〃	−60	−60	−3A	35W (Tc=25°C)	150	−200	−60	100	−4	−1A										268	2SD856とコンプリ	○
	〃 762	〃	〃	〃	−60	−60	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−400	−60	100	−4	−1A										268	2SD857とコンプリ	○
★	〃 763	〃	〃	〃	−60	−60	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−400	−60	120	−4	−1A										365	2SD858とコンプリ	○
	〃 764	三洋	AF.PA	Si.EP	−60	−50	−1A	900	150	−1	−50	60～320	−2	−50	−10	50					150 *	20		294	2SD863とコンプリ	
	〃 765	日立	SW	Si.TP	−120	−120	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−120	1000～20000	−3	−1.5A			t_{on}=0.8μs, t_f=1.5μs t_{stg}=3μs							268	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 766	松下	PA	Si.EP	−30	−25	−1A	500	125	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200 *	20		336	2SD874とコンプリ	○
	〃 767	〃	〃	〃	−80	−80	−500	500	125	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					120 *	20		336	2SD875とコンプリ	
	〃 768	日電	〃	Si.T	−200	−150	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−50	−150	40～200	−10	−400	−10	400					10 *			185	2SD1033とコンプリ	
★	〃 769	〃																								
★	〃 770	〃																								
★	〃 771	〃																								
	〃 772	〃	PA.SW	Si.E	−40	−30	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−30	160	−2	−1A	−5	100					80 *	55		225	2SD882とコンプリ	
★	〃 773	〃	PA	Si.T	−100	−100	−6A	70W (Tc=25°C)	150	−50	−90	80	−5	−1A										295		○
	〃 774	松下	AF	Si.EP	−30	−25	−100	400	150	−1	−10	120～650	−10	−2	−10	2					150 *	4		138	2SD889とコンプリ	
	〃 775	三洋	PA.SW	Si.P	−100	−85	−6A	60W (Tc=25°C)	150	−100	−40	60～200	−5	−1A	−5	1A					13 *	150		346	2SD895とコンプリ	
	〃 776	〃	〃	〃	−120	−100	−7A	70W (Tc=25°C)	150	−100	−80	60～200	−5	−1A	−5	1A					15 *	200		346	2SD896とコンプリ	
	〃 777	富士電機	AF.PA	Si.EP	−80	−80	−10A	80W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	120	−5	−2A										211		
	〃 778	〃	〃	〃	−120	−120	−10A	80W (Tc=25°C)	150	−1mA	−120	120	−5	−2A										211		
	〃 779	松下	AF	〃	−25	−20	−500	200	125	−0.1	−25	65～350	−2	−500	−10	50					150 *	15		176	2SD813とコンプリ	
★	〃 780	〃	〃	〃	−30	−25	−500	400	125	−0.1	−20	60～340	−10	−150	−10	50					200 *	6		276	2SD919とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SB781	日立	PA	Si. T	−50	−50	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−50	200	−5	−500										268	
★	〃 782	〃	〃	〃	−60	−60	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−50	120	−5	−500										268	
★	〃 783	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−60	100	−5	−500										268	
★	〃 784	〃																							
★	〃 785	〃																							
	〃 786	ローム	AF. PA	Si. EP	−40	−40R	−2A	5 W (Tc=25°C)	150	−1	−24	10000	−3	−500	−6	100					150*	11		232	ダーリントン
★	〃 787	日立	〃	Si. E	−120	−80	−50	625	150	−10	−100	120	−5	−10										138D	
	〃 788	松下	AF. LN	Si. EP	−120	−120	−20	400	150	−0.1	−50	180~1040	−5	−2										151	2SD958 とコンプリ
	〃 789	〃	AF	〃	−100	−100	−500	1 W (プリント基板使用)	150			65~330	−10	−150	−10	50					120*	<30		336	2SD968 とコンプリ ○
	〃 790	〃	〃	〃	−25	−20	−500	600	135	−0.1	−25	65~350	−2	−500	−10	50					150*	15		151	2SD969 とコンプリ
	〃 791	日立	SW	Si. T	−120	−120	−8A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−120	1000~20000	−3	−4A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.5μs t_{stg}=1.6μs							268	2SD970 とコンプリ
	〃 792	松下	AF	Si. EP	−150	−150	−50	200	125	−1	−100	90~450	−5	−10	−10	10					200*	4		176	2SD814 とコンプリ
	〃 793	〃	〃	〃	−30	−25	−1A	1 W	150	−0.1	−20	60~340	−10	−500	−10	50					200*	20		151	2SD973 とコンプリ ○
	〃 794	日電	PA. SW	Si. E	−60	−60	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−60	7000	−2	−1A										225	ダーリントン
	〃 795	〃	〃	〃	−80	−80	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−80	7000	−2	−1A										225	ダーリントン
★	〃 796	〃	PA	Si. T	−200	−200	−10A	20W (Tc=25°C)	150	−50	−200	80	−5	−2A	−5	200					14*	450		102	2SD997 とコンプリ
★	〃 797	〃																							
	〃 798	〃	PA	Si. E	−30	−25	−1A	2 W (セラミック基板使用)	150	−0.1	−30	200	−1	−100	−6	10					110*	36		336	2SD999 とコンプリ
	〃 799	〃	〃	〃	−60	−50	−700	2 W (セラミック基板使用)	150	−0.1	−60	200	−1	−100	−6	10					120*	25		336	2SD1000 とコンプリ
	〃 800	〃	AF	〃	−80	−80	−300	2 W (セラミック基板使用)	150	−0.1	−80	190	−1	−50	−6	10					100*	13		336	2SD1001 とコンプリ
	〃 801	〃	〃	〃	−45	−45	−1A	400	150	−0.1	−30	100	−2	−150	−5	10					80*	26		336	
	〃 802	〃	〃	〃	−60	−60	−1A	400	150	−0.1	−30	90	−2	−150	−5	10					80*	26		336	
	〃 803	〃	〃	〃	−100	−100	−1A	400	150	−0.1	−30	90	−2	−150	−5	10					80*	26		336	
	〃 804	〃	〃	〃	−100	−80	−1A	2 W (セラミック基板使用)	150	−0.1	−100	160	−2	−100	−5	10					100*	15		336	2SD1005 とコンプリ
	〃 805	〃	〃	〃	−100	−100	−700	2 W (セラミック基板使用)	150	−0.1	−100	200	−1	−100	−10	10					75*	17		336	2SD1006 とコンプリ
	〃 806	〃	〃	〃	−120	−120	−700	2 W (セラミック基板使用)	150	−0.1	−120	200	−1	−100	−10	10					75*	17		336	2SD1007 とコンプリ
	〃 807	松下	〃	Si. EP	−150	−150	−50	1 W (プリント基板使用)	150	−1	−100	90~450	−5	−10	−10	10					200*	4		336	2SD1009 とコンプリ
	〃 808	三洋	PA	〃	−20	−15	−700	250	125	−1	−15	160~960	−2	−50	−10	50					250*	13		92	2SD1012 とコンプリ
★	〃 809	三菱																							
	〃 810	日電	AF	Si. E	−30	−25	−700	350	150	−0.1	−30	200	−1	−100	−6	10					160*	17		42	2SD1020 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SB811	日電	PA	Si. E	−30	−25	−1A	350	150	−0.1	−30	200	−1	−100	−6	10					110 *	36		42	2SD1021 とコンプリ
★	〃 812	松下	〃	Si. EP	−60	−60	−4A	60W (Tc=25°C)	150	−400	−60	40~250	−4	−3A			t_{on}=0.3μs, t_{off}=1.3μs							365	2SD1032 とコンプリ ○
★	〃 813	三洋	〃	Si. TP	−60	−60	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	100	−2	−1A										268	
★	〃 814	松下	AF. LN	Si. EP	−120	−120	−20	200	125	−0.1	−50	180~700	−5	−2			V_{NO}=100mV (−40V, −1mA, R_G=100kΩ G_V=80dB)							176	
	〃 815	三洋	AF	〃	−20	−15	−700	200	125	−0.1	−15	160~960	−2	−50	−10	50					250 *	13		176	2SD1048 とコンプリ
	〃 816	〃	PA. SW	Si. P	−150	−120	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−80	60~200	−5	−1A	−5	1 A					15 *	220		346	2SD1046 とコンプリ
	〃 817	〃	〃	〃	−160	−140	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−80	60~200	−5	−1A	−5	1 A					15 *	300		346	2SD1047 とコンプリ
	〃 818	日立	AF. PA	Si. E	−100	−100	−10A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−100	2000	−3	−5A										332	ダーリントン ダンパ内蔵
	〃 819	松下	AF	Si. EP	−50	−40	−1.5A	1 W	150	−1	−20	30~220	−5	−1A	−5	500					150 *	45		151	2SD1051 とコンプリ
	〃 820	日電	PA	Si. T	−350	−350	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−300	50	−5	−100										185	
	〃 821	ローム	LN	Si. EP	−50	−40	−300	250	125	−0.5	−30	270	−6	−10	−6	1		8.1k	2.9	19.6	NF=1 dB (f=10MHz)		2	235	
	〃 822	〃	AF	〃	−40	−32	−2A	750	135	−1	−20	180	−3	−500	−5	500					100 *	50		235	2SD1055 とコンプリ
★	〃 823	三洋	PA	〃	−100	−85	−6A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	100	−5	−1A										268	
★	〃 824	〃	〃	〃	−60	−50	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	120	−2	−1A										268	
	〃 825	〃	PA. SW	〃	−60	−50	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	100	−2	−1A			t_{on}<0.2μs, t_f<0.1μs t_{stg}<0.7μs							268	
	〃 826	〃	〃	〃	−60	−50	−12A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	100	−2	−1A			t_{on}<0.2μs, t_f<0.1μs t_{stg}<0.4μs							268	
	〃 827	〃	〃	〃	−60	−50	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−100	−40	100	−2	−1A	−5	1 A	t_{on}<0.2μs, t_f<0.1μs t_{stg}<0.7μs				10 *			346	
	〃 828	〃	〃	〃	−60	−50	−12A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−40	100	−2	−1A	−5	1 A	t_{on}<0.2μs, t_f<0.1μs t_{stg}<0.4μs				10 *			346	
★	〃 829	〃	〃	〃	−60	−50	−15A	90W (Tc=25°C)	150	−100	−40	100	−2	−1A	−5	1 A					20 *			346	
★	〃 830	日立	PA	Si. E	−20	−16	−2A	900	150	−2	−16	220	−2	−100										251	
	〃 831	〃	〃	〃	−25	−20	−700	150	150	−1	−20	140	−1	−150										176	2SD1101 とコンプリ
★	〃 832	ソニー	SW. PA	Si. Pa	−1000	−900	10	25W (Tc=25°C)	120	I_{CES} −10	−1000	>50	−5	−1	−10	1					4.5 *	4.3		268	2SD1068 とコンプリ
	〃 833	東芝	AF. PA. SW	Si. T	−80	−80	−30A	150W (Tc=25°C)	150	−100	−80	4000	−5	−20A			t_{on}< 3 μs, t_f< 4 μs t_{stg}< 10μs							102	ダーリントン ダンパ内蔵
	〃 834	〃	AF. PA	〃	−60	−60	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−60	100	−5	−500										268	2SD880 とコンプリ
	〃 835	松下	AF	Si. EP	−20	−18	−1A	1 W	150	−1	−10	90~360	−2	−500	−6	50					200 *	40		151	
	〃 836	日立	PA	Si. E	−25	−25	−2.5A	20W (Tc=25°C)	150	−20	−25	160	−2	−500										245	
	〃 837	〃	〃	〃	−35	−35	−2.5A	20W (Tc=25°C)	150	−20	−35	160	−2	−500										245	2SD1077 とコンプリ
★	〃 838	〃	〃	〃	−50	−50	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−20	−50	120	−4	−50	−4	50					130 *			245	
★	〃 839	〃	〃	〃	−80	−80	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−20	−80	120	−4	−50	−4	50					130 *			245	
	〃 840	〃	〃	〃	−180	−120	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−10	−160	100	−5	−150	−5	150					140 *	25		245	2SD1080 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SB841	日立	PA	Si. E	−180	−160	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−10	−160	100	−5	−150	−5	150					140*	25		245	2SD1081とコンプリ	
★	〃 842	〃	〃	〃	−200	−160	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−10	−160	100	−5	−150										245		
★	〃 843	〃	AF. PA	〃	−50	−50	−5A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−20	280	−2	−500										160		
★	〃 844	〃	PA	〃	−120	−80	−1A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−100	160	−5	−150										245		
★	〃 845	〃	〃	〃	−120	−100	−1A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−100	100	−5	−150										245		
★	〃 846	〃	〃	〃	−25	−20	−1A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−20	130	−2	−500										245		
★	〃 847	日電																								
★	〃 848	〃	PA	Si. T	−100	−100	−6A	70W (Tc=25°C)	150	−50	−100	80	−5	−1A										162		
	〃 849	〃	〃	〃	−120	−120	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−50	−120	80	−5	−1A	−5	200					14*	340		162	2SD1110とコンプリ	○
	〃 850	富士電機	〃	Si. EP	−40	−40	−10A	50W (Tc=25°C)	150	−10	−40	120	−5	−2A										268		○
	〃 851	ローム	AF	〃	−80	−80	−700	750	135	−0.5	−50	180	−3	−100	−10	50					100*	14		235		
	〃 852	〃	〃	〃	−40	−32	−300	200	125	−1	−24	10000	−5	−100	−5	10					200*	3		335	ターリントン	
	〃 853	日立	PA. SW	Si. E	−100	−100	−15A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−100	3000	−3	−8A			t_{on}<2.5μs, t_{off}<10μs t_{stg}<4μs							332	ターリントン	
	〃 854	〃	〃	〃	−100	−100	−20A	125W (Tc=25°C)	150	−100	−100	3000	−3	−10A			t_{on}<2.5μs, t_{off}<10μs t_{stg}<4μs							332	ターリントン	
	〃 855	〃	PA	Si. T	−50	−50	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−20	100	−4	−1A	−4	500					35*			268		
	〃 856	〃	〃	〃	−50	−50	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−20	100	−4	−1A	−4	500					35*			268		
	〃 857	〃	〃	〃	−70	−50	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−1	−50	100	−4	−1A	−4	500					15*			268	2SD1133とコンプリ	
	〃 858	〃	〃	〃	−70	−60	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−1	−50	100	−4	−1A	−4	500					15*			268	2SD1134とコンプリ	
	〃 859	〃	〃	〃	−100	−80	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	100	−5	−1A	−4	500					20*	75		268	2SD1135とコンプリ	
	〃 860	〃	〃	〃	−100	−100	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	120	−4	−500										268	2SD1137とコンプリ	
	〃 861	〃	〃	〃	−200	−150	−2A	30W (Tc=25°C)	150	−1	−120	140	−4	−50								30		268	2SD1138とコンプリ	
	〃 862	富士電機	AF. PA	Si. EP	−120	−80	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−1mA	−120	5000	−5	−1A	−5	500					68*	72		268	ターリントン	
	〃 863	東芝	PA	Si. T	−140	−140	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−5	−140	100	−5	−1A										203	2SD1148とコンプリ	
★	〃 864	日立		Si. E	−55	−55	−100	300	125	−0.1	−18	300	−10	−10										138		
	〃 865	三洋	AF. SW	Si. EP	−80	−50	−1.5A	900	150	−0.1	−40	23000	−2	−500	−10	50					120*			294	2SD1153とコンプリ	
★	〃 866																									
	〃 867	松下	PA. SW	Si. TP	−130	−80	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	150	−2	−500	−10	500	t_{on}<1μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3μs				30*			268	2SD959とコンプリ	
	〃 868	〃	〃	〃	−130	−80	−4A	35W (Tc=25°C)	150	−10	−100	150	−2	−1A	−10	500	t_{on}<1μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3μs				30*			268	2SD960とコンプリ	
	〃 869	〃	〃	〃	−130	−80	−5A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	150	−2	−2A	−10	500	t_{on}<1μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3μs				30*			268	2SD961とコンプリ	
	〃 870	〃	〃	〃	−130	−80	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	150	−2	−3A	−10	500	t_{on}<1μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3μs				30*			268	2SD866とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SB871	松下	PA. SW	Si. P	−40	−20	−10A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	200	−2	−3A	−10	500	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs				100 *			268	2SD1443 とコンプリ	○
	〃 872	〃	〃	〃	−60	−60	−8A	45W (Tc=25°C)	150	−100	−60	4000	−3	−4A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 6 μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵	○
	〃 873	〃	PA	Si. EP	−30	−20	−5A	1 W	150	−0.1	−10	220	−2	−2A	−6	50					120 *	60		294	2SD966 とコンプリ	
	〃 874	日立	AF. PA	Si. E	−100	−60	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−0.1	−80	100	−5	−500	−5	500					250 *	50		160	2SD1177 とコンプリ	
★	〃 875	〃	〃	〃	−100	−80	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−10	−80	100	−5	−500										160		
★	〃 876	〃	〃	〃	−120	−100	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−10	−100	100	−5	−150										160		
★	〃 877	〃	〃	〃	−120	−110	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−10	−100	100	−5	−150										160		
★	〃 878	〃	〃	〃	−180	−120	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−160	100	−5	−150										234D		
★	〃 879	〃	〃	〃	−180	−160	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−160	100	−5	−150										234D		
	〃 880	三洋	〃	Si. EP	−70	−60	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−2A										268	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 881	〃	〃	〃	−70	−60	−7A	35W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−3.5A										268	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 882	〃	〃	〃	−70	−60	−10A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−5A										268	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 883	〃	〃	〃	−70	−60	−15A	70W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−7A										346	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 884	〃	〃	〃	−110	−100	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−80	4000	−3	−1.5A										268	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 885	〃	〃	〃	−110	−100	−5A	35W (Tc=25°C)	150	−100	−80	4000	−3	−2.5A										268	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 886	〃	〃	〃	−110	−100	−8A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	4000	−3	−4A										268	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 887	〃	〃	〃	−110	−100	−10A	70W (Tc=25°C)	150	−100	−80	4000	−3	−5A	−5	5 A					20 *			346	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 888	〃	AF	〃	−80	−50	−700	600	150	−100	−40	25000	−2	−50										138	ダーリントン	
	〃 889	ローム	AF. PA	〃	−80	−80	−700	5 W (Tc=25°C)	150	−0.5	−50	180	−3	−100	−10	50					100 *	14		232	2SD1200 とコンプリ	
★	〃 890	〃	AF	〃	−50	−50	−500	400	125	−1	−30	180	−3	−100										138		
	〃 891	〃	AF. PA	〃	−40	−32	−2A	5 W (Tc=25°C)	150	−1	−20	180	−5	−500	−5	150					100 *	50		232	2SD1189 とコンプリ	
	〃 892	三洋	PA	〃	−60	−50	−2A	1 W	150	−0.1	−50	200	−2	−500										294		
	〃 893	〃	AF	〃	−20	−10	−3A	750	150	−1	−20	300	−2	−500										138	2SD879 とコンプリ	
	〃 894	松下	〃	〃	−30	−25	−100	400	150	−1	−10	300	−10	−2	−10	2					150 *	4		151	2SD1206 とコンプリ	
	〃 895	〃	〃	〃	−30	−25	−1A	1.2W	150	−100	−25	8000	−10	−1A										222	ダーリントン	○
	〃 896	〃	PA. SW	Si. P	−40	−20	−10A	35W (Tc=25°C)	150	−50	−40	130	−2	−2A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 1 μs							268		○
	〃 897	日電	PA	Si. E	−100	−100	−10A	80W (Tc=25°C)	150	−10	−100	5000	−2	−10A	−10	500					150 *	200		162	ダーリントン ダンパ内蔵	
★	〃 898	日立	AF. PA	Si. T	−50	−50	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−20	110	−4	−1A										267		
★	〃 899	〃	〃	〃	−50	−50	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−20	100	−4	−1A										268		
★	〃 900	〃	〃	〃	−50	−50	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−20	120	−4	−1A										268		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SB901	日立	AF. PA	Si. T	−60	−60	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−20	120	−4	−1A										268		
	〃 902	松下	AF	Si. EP	−30	−25	−100	200	125	−1	−10	300	−10	−2	−10	2					150*	4		176		
	〃 903	三洋	PA	〃	−60	−30	−12A	35W (Tc=25°C)	150	−100	−40	140	−2	−1A										268		
	〃 904	〃	〃	〃	−60	−30	−20A	60W (Tc=25°C)	150	−100	−40	140	−2	−1A										346		
	〃 905	東芝	〃	Si. E	−150	−150	−1.5A	1 W	150	−1	−150	120	−5	−200	−5	200					50*	<3.5		344	2SD1220とコンプリ	
	〃 906	〃	AF. PA	Si. T	−60	−60	−3A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−60	100	−5	−500	−5	500					9*	150		344	2SD1221とコンプリ	
	〃 907	〃	PA	Si. E	−60	−40	−3A	1 W	150	−1	−60	5000	−2	−1A										344	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 908	〃	〃	〃	−100	−80	−4A	1 W	150	−1	−100	5000	−2	−1A										344	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 909	ローム	AF	Si. EP	−40	−32	−1A	1 W	135	−0.5	−20	180	−3	−100										235		
	〃 910	〃	〃	〃	−80	−80	−700	1 W	135	−0.5	−50	180	−3	−100										235		
	〃 911	〃	〃	〃	−40	−32	−2A	1 W	135	−1	−20	180	−3	−500										235		
★	〃 912	三洋	PA	〃	−70	−60	−10A	60W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−5A										346	ダーリントンダンパ内蔵	
★	〃 913	〃	〃	〃	−110	−100	−8A	60W (Tc=25°C)	150	−100	−80	4000	−3	−4A										346	ダーリントンダンパ内蔵	
★	〃 914	〃	〃	〃	−70	−60	−10A	70W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−5A	−5	5 A	t_{on}=0.5μs, t_f=1.7μs t_{stg}=1.5μs				20*			102	ダーリントンダンパ内蔵	
★	〃 915	〃	〃	〃	−70	−60	−15A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−7A	−5	7 A					20*			102	ダーリントンダンパ内蔵	
★	〃 916	〃	〃	〃	−110	−100	−8A	70W (Tc=25°C)	150	−100	−80	4000	−3	−4A										102	ダーリントンダンパ内蔵	
★	〃 917	〃	〃	〃	−110	−100	−10A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−80	4000	−3	−5A	−5	5 A					20*			102	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 918	富士通	AF	〃	−250	−250	−500	500	150	−0.5	−200	70	−2	−100										138		
	〃 919	三洋	PA	〃	−60	−30	−8A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	150	−2	−1A	−5	1 A	t_{on}=0.1μs, t_f=0.03μs t_{stg}=0.2μs				120*			268		
	〃 920	〃	〃	〃	−120	−80	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−80	150	−2	−1A										268		
	〃 921	〃	〃	〃	−120	−80	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	150	−2	−1A										268		
	〃 922	〃	〃	〃	−120	−80	−12A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−80	150	−2	−1A	−5	1 A					20*			346	2SD1238とコンプリ	
★	〃 923	〃	〃	〃	−120	−80	−20A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−80	150	−2	−1A										102		
★	〃 924	〃	〃	〃	−120	−80	−25A	120W (Tc=25°C)	150	−100	−80	150	−2	−1A										102		
	〃 925	松下	SW	Si. P	−40	−20	−7A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−40	60~260	−2	−2A	−10	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				150*	140		268		○
	〃 926	三洋	AF	Si. EP	−30	−25	−2A	750	150	−0.1	−20	300	−2	−100										138	2SD1246とコンプリ	
	〃 927	〃	PA	〃	−30	−25	−2.5A	1 W	150	−0.1	−20	300	−2	−100										294		
	〃 928	松下	〃	〃	−200	−150	−2A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−200	60~240	−10	−150										363	2SD1250とコンプリ	○
	〃 929	〃	〃	〃	−60	−60	−3A	35W (Tc=25°C)	150			40~250	−4	−1A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.3μs t_s=1.2μs							363	2SD1252とコンプリ	○
	〃 930	〃	〃	〃	−60	−60	−4A	40W (Tc=25°C)	150			40~250	−4	−1A			t_{on}=0.2μs, t_f=0.2μs t_s=0.5μs							363	2SD1253とコンプリ	○

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
2SB931	松下	SW	Si. EP	−130	−80	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	60~260	−2	−0.5A	−10	500	t_{on}=0.3μs, t_f=0.3μs t_s=1.1μs				30*			363	2SD1254 とコンプリ	
〃 932	〃	〃	〃	−130	−80	−4A	35W (Tc=25°C)	150	−10	−100	60~260	−2	−1A	−10	500	t_{on}=0.15μs, t_f=0.15μs t_s=0.8μs				30*			363	2SD1255 とコンプリ	
〃 933	〃	〃	〃	−130	−80	−5A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	60~260	−2	−2A	−10	500	t_{on}=0.13μs, t_f=0.13μs t_s=0.5μs				30*			363	2SD1256 とコンプリ	
〃 934	〃	〃	〃	−130	−80	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	60~260	−2	−3A	−10	500	t_{on}=0.5μs, t_f=0.1μs t_s=1.5μs				30*			363	2SD1257 とコンプリ	
〃 935	〃	〃	〃	−40	−20	−10A	35W (Tc=25°C)	150	−50	−40	60~260	−2	−2A	−10	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				150*	200		363		○
〃 936	〃	〃	〃	−40	−20	−10A	40W (Tc=25°C)	150	−50	−40	60~260	−2	−3A	−10	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				100*	400		363		○
〃 937	〃	PA. SW	〃	−60	−60	−2A	35W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	1000~10000	−4	−2A			t_{on}=0.4μs, t_f=0.5μs t_s=1.5μs							363	ダーリントン 2SD1260 とコンプリ	○
〃 938	〃	〃	〃	−60	−60	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−200	−60	1000~10000	−3	−3A			t_{on}=0.3μs, t_f=0.5μs t_s=2.0μs							363	ダーリントン 2SD1261 とコンプリ	○
〃 939	〃	SW	〃	−60	−60	−8A	45W (Tc=25°C)	150	−100	−60	1000~10000	−3	−4A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.0μs t_s=2.0μs							363	ダーリントン 2SD1262 とコンプリ	○
〃 940	〃	PA	〃	−200	−150	−2A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−200	60~240	−10	−150										364	2SD1264 とコンプリ	○
〃 941	〃	〃	〃	−60	−60	−3A	35W (Tc=25°C)	150			40~250	−4	−1A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.3μS t_s=1.2μs							364	2SD1266 とコンプリ	○
〃 942	〃	〃	〃	−60	−60	−4A	40W (Tc=25°C)	150			40~250	−4	−1A										364	2SD1267 とコンプリ	○
〃 943	〃	SW	〃	−130	−80	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	60~260	−2	−0.5A	−10	500	t_{on}=0.3μs, t_f=0.3μs t_s=1.1μs				30*			364	2SD1268 とコンプリ	
〃 944	〃	〃	〃	−130	−80	−4A	35W (Tc=25°C)	150	−10	−100	60~260	−2	−1A	−10	500	t_{on}=0.15μs, t_f=0.15μs t_s=0.8μs				30*			364	2SD1269 とコンプリ	
〃 945	〃	〃	〃	−130	−80	−5A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	60~260	−2	−2A	−10	500	t_{on}=0.13μs, t_f=0.13μs t_s=0.5μs				30*			364	2SD1270 とコンプリ	
〃 946	〃	〃	〃	−130	−80	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	60~260	−2	−3A	−10	500	t_{on}=0.5μs, t_f=0.1μs t_s=1.5μs				30*			364	2SD1271 とコンプリ	
〃 947	〃	〃	〃	−40	−20	−10A	35W (Tc=25°C)	150	−50	−40	60~260	−2	−2A	−10	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				150*	200		364		○
〃 948	〃	〃	〃	−40	−20	−10A	40W (Tc=25°C)	150	−50	−40	60~260	−2	−3A	−10	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				100*	400		364	2SD1445 とコンプリ	○
〃 949	〃	PA. SW	〃	−60	−60	−2A	35W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	1000~10000	−4	−2A			t_{on}=0.4μs, t_f=0.5μs t_s=1.5μs							364	ダーリントン 2SD1275 とコンプリ	○
〃 950	〃	〃	〃	−60	−60	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−200	−60	1000~10000	−3	−3A			t_{on}=0.3μs, t_f=0.5μs t_s=2.0μs							364	ダーリントン 2SD1276 とコンプリ	○
〃 951	〃	SW	〃	−60	−60	−8A	45W (Tc=25°C)	150	−100	−60	1000~10000	−3	−4A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.0μs t_s=2.0μs							364	ダーリントン 2SD1277 とコンプリ	○
〃 952	〃	〃	〃	−40	−20	−7A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−40	60~260	−2	−2A	−10	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				150*	140		363		○
〃 953	〃	〃	〃	−40	−20	−7A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−40	60~260	−2	−2A	−10	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				150*	140		364	2SD1444 とコンプリ	○
〃 954	〃	PA	〃	−60	−60	−1A	30W (Tc=25°C)	150	−200	−60	150	−4	−200			t_{on}=0.5μs, t_f=0.3μs t_{stg}=1.2μs							364		○
〃 955	日立	〃	Si. T	−120	−120	−10A	50W (Tc=25°C)	150	−100	−120	4000	−3	−5A										268	ダーリントン ダンパ内蔵	
〃 956	松下	AF	Si. EP	−20	−20	−1A	1 W (Tc=25°C)	150	−1	−10	90~360	−2	−500	−6	50					200*	40		336	2SD1280 とコンプリ	
〃 957	日立	PA	Si. E	−100	−60	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−80	100	−5	−500	−5	500					250*	40		245	2SD1281 とコンプリ	
★ 〃 958	〃	〃	〃	−100	−80	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−0.1	−80	100	−5	−500										245		
★ 〃 959	〃	〃	〃	−120	−100	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−0.1	−100	100	−5	−150										245		
★ 〃 960	〃	〃	〃	−120	−110	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−0.1	−100	100	−5	−150										245		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SB961	ソニー																							
〃 962	日電	PA	Si. E	−40	−30	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−30	150	−2	−1A										186	
〃 963	〃	〃	〃	−60	−60	∓1A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−60	6000	−2	−500										186	ダーリントンダンパ内蔵
〃 964	〃	〃	〃	−60	−60	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−1mA	−60	8000	−2	−1A										186	ダーリントンダンパ内蔵
〃 965	〃	AF. PA	〃	−120	−120	−7A	70W (Tc=25°C)	150	−50	−120	140	−5	−1A										162	
〃 966	〃	〃	〃	−120	−120	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−50	−120	140	−5	−1A										162	
〃 967	松下	PA	Si. EP	−30	−20	−5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−10	300	−2	−2A	−6	50					120*	<85		361	
〃 968	〃	〃	〃	−50	−40	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−20	100	−5	−1A	−5	500					150*	45		361	2SD1295とコンプリ
〃 969	日電	〃	Si. E	−100	−100	−15A	100W (Tc=25°C)	150	−10	−100	5000	−2	−10A										162	ダーリントンダンパ内蔵
〃 970	松下	AF	Si. EP	−15	−10	−500	200	125	−0.1	−10	200	−2	−500	−10	50					130*	22		176	2SD1328とコンプリ
〃 971	〃	PA	〃	−20	−20	−1A	1W	150	−1	−10	200	−2	−500										294	2SD1303とコンプリ
〃 972	日立	AF	Si. E	−7	−7	−500	150	150	−0.2	−5	300	−1	−400										176	
〃 973	〃	〃	〃	−10	−10	−700	150	150	−100	−5	100~320	−1	−400	−1	100					280*	47		176	
〃 974	日電	PA	〃	−100	−100	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	6000	−2	−2A										370	ダーリントンダンパ内蔵
〃 975	〃	〃	〃	−100	−100	−8A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	6000	−2	−3A										370	ダーリントンダンパ内蔵
〃 976	松下	AF. PA	Si. EP	−25	−18	−5A	750	150	−0.1	−10	200	−2	−2A	−6	50					120*	60		138	
〃 977	〃	AF	〃	−30	−25	−1A	750	150	−0.1	−25	2000~20000	−10	−1A										138	ダーリントン,○
〃 978	日立	〃	Si. E	−40	−40	−1.5A	900	150	−1	−30	200	−2	−100										251	
★ 〃 979	松下	AF. PA	Si. TP	−100	−100	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−50	−100	100	−5	−1A	−5	500					20*	170		365	2SD1332とコンプリ
★ 〃 980	〃	〃	〃	−120	−120	−6A	70W (Tc=25°C)	150	−50	−120	100	−5	−1A										365	
★ 〃 981	〃	〃	〃	−140	−140	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−50	−140	100	−5	−1A										365	
★ 〃 982	〃	〃	〃	−150	−150	−9A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−150	100	−5	−1A										365	
〃 983	新電元	SW	Si. EP	−60	−50	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	70~200	−2	−1A	−5	1A	t_{on}=0.2μs, t_{stg}=0.7μs	t_f=0.1μs			10*			268	2SD1345とコンプリ
〃 984	日電	AF. PA	Si. E	−120	−80	−1A	1W	150	−0.1	−100	230	−1	−200										278	
〃 985	三洋	AF	Si. EP	−60	−50	−4A	1W	150	−1	−40	250	−2	−500	−10	50					150*	39		294	2SD1347とコンプリ
〃 986	〃	〃	〃	−60	−50	−4A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−40	250	−2	−500	−10	50					150*	39		296	2SD1348とコンプリ
〃 987	松下	AF. PA	〃	−120	−120	−500	1W	150	−0.1	−10	200	−10	−500	−10	50					250*	<30		294	2SD1211とコンプリ
〃 988	韓国電子	〃	Si. T	−60	−60	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−60	115	−5	−500	−5	500	t_{on}=0.4μs, t_{stg}=1.7μs	t_f=0.5μs			9*	150		268	2SD1351とコンプリ
〃 989	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−30	−80	115	−5	−500	−5	500					>3*	130		268	2SD1352とコンプリ
★ 〃 990																								

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SB991	三洋	AF.PA	Si.EP	−180	−180	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−10	−80	100	−5	−300	−5	100					8*			300	
★	〃 992	東芝	PA.SW	Si.T	−100	−80	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−5	−100	120	−1	−1A			t_{on}<1.2μs, t_{stg}<7.5μs				t_f<1.5μs			51	2SD1362とコンプリ
★	〃 993	〃	〃	〃	−70	−50	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−30	−70	120	−1	−1A			t_{on}<0.6μs, t_{stg}<7.5μs				t_f<1.5μs			51	2SD1363とコンプリ
★	〃 994	〃	PA	〃	−60	−60	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−60	100	−5	−500										51	2SD1354とコンプリ
★	〃 995	〃	〃	〃	−100	−100	−5A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−100	100	−5	−500										51	2SD1355とコンプリ
★	〃 996	〃	〃	〃	−80	−80	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−30	−80	100	−5	−500										51	2SD1356とコンプリ
★	〃 997	〃	AF.PA.SW	〃	−100	−100	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−100	6000	−3	−3A			t_{on}<2.5μs, t_{stg}<12μs				t_f<5μs			51	ダーリントンダンパ内蔵
★	〃 998	〃	〃	〃	−80	−80	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	6000	−3	−3A			t_{on}<2.5μs, t_{stg}<12μs				t_f<5μs			51	ダーリントンダンパ内蔵
★	〃 999	〃	〃	〃	−60	−60	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−60	6000	−3	−3A			t_{on}<2.5μs, t_{stg}<12μs				t_f<5μs			51	ダーリントンダンパ内蔵
	〃 1000	日立	AF	Si.E	−25	−20	−1A	1W (プリント基板使用)	150	−0.1	−20	120	−2	−500	−2	500					200*	38		336	2SD1366とコンプリ ○
	〃 1001	〃	〃	〃	−20	−16	−2A	1W (プリント基板使用)	150	−0.1	−16	200	−2	−100	−2	10					150*	50		336	2SD1367とコンプリ
	〃 1002	〃	〃	〃	−70	−50	−1A	1W (プリント基板使用)	150	−0.1	−50	200	−2	−100	−2	10					150*	35		336	2SD1368とコンプリ
★	〃 1003	東芝	AF.PA.SW	Si.T	−60	−40	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−20	−60	5000	−2	−1A			t_{on}<0.6μs, t_{stg}<1.5μs				t_f<0.5μs			51	ダーリントンダンパ内蔵
★	〃 1004	〃	〃	〃	−100	−80	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−20	−100	4000	−2	−1A			t_{on}<0.3μs, t_{stg}<1.8μs				t_f<1.5μs			51	ダーリントンダンパ内蔵
	〃 1005	サンケン	AF.PA	Si.EP	−50	−50	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−50	3000	−4	−3A										298	ダーリントンダンパ内蔵
★	〃 1006																								
	〃 1007	ローム	AF.PA	Si.EP	−80	−80	−700	10W (Tc=25°C)	150	−0.5	−50	180	−3	−100	−10	50					100*	14		74	2SD1378とコンプリ
	〃 1008	〃	〃	〃	−40	−40	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−24	20000	−3	−500	−6	100					150*	11		74	ダーリントン
	〃 1009	〃	AF	〃	−40	−32	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−20	180	−5	−500	−5	500					100*	50		74	2SD1380とコンプリ
	〃 1010	〃	〃	〃	−40	−32	−2A	750	125	−1	−20	180	−3	−500	−5	500					100*	50		294	2SD1384とコンプリ
	〃 1011	松下	〃	Si.TP	−400	−400	−100	1.2W	150	−10	−100	150	−50	−5	−30	20					70*	<9		222	
	〃 1012	日立	PA	Si.E	−120	−120	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−1A										160	ダーリントンダンパ内蔵
★	〃 1013	三洋	AF	Si.EP	−20	−16	−2A	700	150	−0.1	−20	250	−2	−100										138	2SD1387とコンプリ
★	〃 1014	〃	〃	〃	−60	−50	−1A	700	150	−0.1	−20	250	−2	−100										138	2SD1388とコンプリ
	〃 1015	東芝	PA	Si.T	−60	−60	−3A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−60	110	−5	−500										381	2SD1406とコンプリ
	〃 1016	〃	〃	〃	−100	−100	−5A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−100	100	−5	−1A										381	2SD1407とコンプリ
	〃 1017	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	20W (Tc=25°C)	150	−30	−80	100	−5	−1A										381	2SD1408とコンプリ
	〃 1018	〃	PA.SW	〃	−100	−80	−7A	25W (Tc=25°C)	150	−5	−100	120	−1	−1A			t_{on}<1.2μs, t_{stg}<7.5μs				t_f<1.5μs			381	
	〃 1019	〃	〃	〃	−70	−50	−7A	75W (Tc=25°C)	150	−30	−70	120	−1	−1A			t_{on}<0.6μs, t_{stg}<7.5μs				t_f<1.5μs			381	
	〃 1020	〃	〃	〃	−100	−100	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−100	6000	−3	−3A			t_{on}<2.5μs, t_{stg}<12μs				t_f<5μs			381	ダンパ内蔵ダーリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SB1021	東芝	PA. SW	Si. T	−80	−80	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	6000	−3	−3A			t_{on}<2.5μs, t_f<5μs t_{stg}<12μs							381	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1022	〃	〃	〃	−60	−60	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−60	6000	−3	−3A			t_{on}<2.5μs, t_f<5μs t_{stg}<12μs							381	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1023	〃	〃	〃	−60	−40	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−20	−60	5000	−2	−1A			t_{on}<0.6μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							381	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1024	〃	〃	〃	−100	−80	−4A	30W (Tc=25°C)	150	−20	−100	4000	−2	−1A			t_{on}<0.3μs, t_f<1.5μs t_{stg}<1.8μs							381	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1025	日立	AF. PA	Si. E	−120	−80	−1A	1 W (プリント基板使用)	150	−10	−100	150	−5	−100	−5	150					140*	20		336	2SD1418とコンプリ
〃 1026	〃	〃	〃	−120	−100	−1A	1 W (プリント基板使用)	150	−10	−100	110	−5	−100	−5	150					140*	20		336	2SD1419とコンプリ
〃 1027	〃	〃	〃	−180	−120	−1.5A	500	150	−10	−160	150	−5	−100										336	2SD1420とコンプリ
〃 1028	〃	〃	〃	−180	−160	−1.5A	500	150	−10	−160	100	−5	−100										336	2SD1421とコンプリ
〃 1029	〃	〃	〃	−100	−60	−2A	500	150	−0.1	−80	110	−5	−100										336	2SD1422とコンプリ
〃 1030	松下	AF	Si. EP	−30	−25	−500	300	125	−0.1	−20	200	−10	−150										376	
〃 1031	日立	PA	Si. E	−100	−100	−15A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−100	5000	−3	−8A										373	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1032	〃	〃	Si. T	−120	−120	−10A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−5A										373	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1033	ローム	〃	Si. EP	−80	−60	−3A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−50	120	−5	−1A	−5	500					12*	100		268	2SD1437とコンプリ
★ 〃 1034	東芝	PA. SW	Si. E	−80	−80	−2A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−80	5000	−2	−1A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<6μs							342	ダーリントン
〃 1035	三菱	AF. PA	〃	−30	−25	−1A	900	150	−1	−25	150	−1	−500	−6	10					100*			6	2SD1447とコンプリ
〃 1036	松下	LN	Si. EP	−120	−120	−20	300	125	−1	−50	350	−5	−2			NF=1.5dB (−5V, −1mA, 1kHz)							376	
〃 1037	三洋	PA	〃	−150	−150	−1.5A	30W (Tc=25°C)	175	−10	−120	70~200	−5	−300	−5	100					15*			268	2SD1459とコンプリ
〃 1038	日電	〃	Si. E	−60	−60	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−60	100	−5	−500	−5	100					20*	70		370	2SD1310とコンプリ
〃 1039	〃	〃	〃	−100	−100	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	100	−5	−500	−5	100					20*			370	
〃 1040	〃	AF. PA	〃	−20	−16	−2A	600	150	−0.1	−20	400	−2	−100										186	
〃 1041	ローム	AF	Si. EP	−80	−80	−1A	900	135	−1	−60	180	−3	−100										294	2SD1292とコンプリ
〃 1042	〃	〃	〃	−80	−80	−1A	1 W	135	−1	−60	180	−3	−100										360	
〃 1043	〃	〃	〃	−50	−50	−1A	900	135	−1	−30	180	−3	−100										294	
〃 1044	〃	〃	〃	−50	−50	−1A	1 W	135	−1	−30	180	−3	−100										360	
〃 1045	日立	〃	Si. E	−120	−100	−50	1 W (セラミック基板使用)	150	−10	−100	120	−5	−10	−5	10					140*	4		336	2SD1463とコンプリ
〃 1046	〃	〃	〃	−180	−160	−50	1 W (セラミック基板使用)	150	−10	−160	135	−5	−10	−10	10					140*	4.5		336	2SD1464とコンプリ
〃 1047	〃	PA	〃	−180	−120	−50	1 W (セラミック基板使用)	150	−10	−160	2000~30000	−3	−1A	−10	10								245	2SD1465とコンプリ
〃 1048	日立	AF	Si. E	−60	−60	−1A	500	150	−10	−60	5000	−3	−500										336	ダーリントン
〃 1049	松下	〃	Si. EP	−30	−25	−100	400	150	−0.1	−10	300	−10	−2										151	
〃 1050	〃	〃	〃	−30	−20	−5A	1 W	150	−0.1	−10	200	−2	−2A										151	2SD1244とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★ 2SB1051	ローム	AF	Si.EP	−40	−32	−300	200	125	−0.5	−20	180	−3	−100										335	
〃 1052	松下	PA	〃	−60	−60	−2A	25W (Tc=25°C)	150	−200	−60	100	−4	−1A										364	2SD1480 とコンプリ
〃 1053	〃	AF	〃	−40	−40	−100	200	125	−0.1	−40	150	−10	−5										176	
〃 1054	〃	PA	Si.TP	−100	−100	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−50	−100	100	−5	−1A										82	2SD1485 とコンプリ
〃 1055	〃	〃	〃	−120	−120	−6A	70W (Tc=25°C)	150	−50	−120	100	−5	−1A										82	2SD1486 とコンプリ
〃 1056	〃	〃	〃	−140	−140	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−50	−140	100	−5	−1A										82	2SD1487 とコンプリ
〃 1057	〃	〃	〃	−150	−150	−9A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−150	100	−5	−1A										82	2SD1488 とコンプリ
〃 1058	日立	AF	Si.EP	−20	−16	−2A	750	150	−2	−16	200	−2	−100	−2	10					80 *	50		138	2SD1489 とコンプリ
〃 1059	〃	〃	〃	−70	−50	−1A	750	150	−1	−55	170	−2	−100	−2	10					65 *	35		138	2SD1490 とコンプリ
★ 〃 1060	〃	〃	Si.E	−70	−50	−1A	1W	150	−0.2	−55	220	−2	−100										379	
〃 1061	日電	PA.SW	〃	−300	−300	−300	15W (Tc=25°C)	150	−10	−300	6000	−1.5	−100	−1.5	20					15 *	50		268	ダーリントン
〃 1062	松下	AF	Si.EP	−15	−10	−500	600	150	−0.1	−10	200	−2	−500										151	
〃 1063	〃	PA	〃	−100	−100	−5A	40W (Tc=25°C)	150	−50	−100	100	−5	−1A										364	
〃 1064	ローム	AF.PA	〃	−60	−50	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−1	−40	120	−3	−500	−5	500					70 *	50		268	2SD1505 とコンプリ
〃 1065	〃	〃	〃	−60	−50	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−40	120	−3	−500								40		74	2SD1506 とコンプリ
〃 1066	〃	〃	〃	−60	−50	−3A	1W	150	−1	−40	120	−3	−500								40		383	
〃 1067	東芝	AF.PA.SW	Si.E	−80	−80	−2A	1.5W	150	−10	−80	5000	−2	−1A			t_{on} < 1 μs, t_f < 1 μs t_{stg} < 6 μs							384	ダーリントン
〃 1068	日電	PA	〃	−20	−16	−2A	750	150	−0.1	−16	350	−2	−100	−10	50					180 *	60		138	2SD1513 とコンプリ
〃 1069	松下	AF.PA	Si.EP	−40	−20	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−50	−40	120	−2	−1A										268	
〃 1070	〃	〃	〃	−40	−20	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−50	−40	120	−2	−1A										363	
〃 1071	〃	〃	〃	−40	−20	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−50	−40	120	−2	−1A										364	
〃 1072	日立	〃	Si.T	−100	−80	−4A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−80	3000	−3	−2A										245	ダンパ内蔵 2SD1520 とコンプリ
〃 1073	松下	AF	Si.EP	−30	−20	−5A	500	150	−0.1	−10	200	−2	−2A										336	
〃 1074	〃	AF.PA	Si.TP	−400	−400	−500	1W	150	−1	−100	100	−50	−5										151	
〃 1075	〃	〃	SiEP	−50	−40	−2A	1.2W	150	−1	−20	200	−5	−1A										222	
〃 1076	ローム	PA	〃	−40	−40	−2A	1W	135	−1	−24	20000	−3	−500	−6	−100					150 *			360	ダーリントン
〃 1077	日立	AF	Si.T	−60	−60	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−60	5000	−3	−2A										268	ダーリントン
〃 1078	〃	〃	〃	−120	−120	−8A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−4A										268	ダーリントン
〃 1079	〃	AF.PA	〃	−100	−100	−20A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−100	5000	−3	−10A										373	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1080	〃	AF	Si.E	−35	−35	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−20	−30	200	−2	−500										234D	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★ 2SB1081																								
★ 〃 1082																								
★ 〃 1083																								
★ 〃 1084																								
〃 1085	ローム	AF. PA	Si. EP	−120	−120	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−100	120	−5	−100	−5	100					50 *	30		268	2SD1562 とコンプリ ○
〃 1086	〃	〃	〃	−120	−120	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−100	120	−5	−100	−5	100					40 *	30		74	2SD1563 とコンプリ
〃 1087	日電	PA. SW	Si. E	−100	−100	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	2000〜20000	−2	−2A			t_{on}=0.5μs, t_f=1μs t_{stg}=1μs							268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1088	〃	PA. SW	〃	−100	−100	∓10A	60W (Tc=25°C)	150	−10	−100	6000	−2	−10A			t_{on}<1μs, t_f<2μs t_{stg}<5μs							370	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1089	〃	PA	〃	−60	−60	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−60	100	−5	−500	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−2A, IB=−0.2A)							20 *	70		268	2SD1567 とコンプリ
〃 1090	〃	〃	〃	−100	−100	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	100	−5	−500	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−3A, IB=−0.3A)							20 *			268	2SD1568 とコンプリ
〃 1091	日立	AF. PA	Si. T	−60	−60	−8A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−60	5000	−3	−4A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−4A, IB=−8mA)										268	ダーリントン
〃 1092	〃	〃	Si. E	−80	−80	−1.5A	8 W (Tc=25°C)	150	−100	−80	10000	−3	−1A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−1A, IB=−1mA)										160	ダーリントン
〃 1093	日電	AF.PA.SW	〃	−80	−80	∓1.5A	1 W	150	−10	−80	2000〜30000	−2	−1A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−1A, IB=−1mA)										278	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1094	〃	PA	〃	−60	−60	−3A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−60	100	−5	−500	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−2A, IB=−0.2A)							20 *	70		96	2SD1585 とコンプリ
〃 1095	〃	〃	〃	−100	−100	−4A	20W (Tc=25°C)	150	−10	−100	100	−5	−500	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−3A, IB=−0.3A)							20 *			96	2SD1586 とコンプリ
〃 1096	〃	〃	Si. T	−200	−150	−2A	25W (Tc=25°C)	150	−50	−150	90	−10	−400	$V_{CE(sat)}$<−1V $V_{BE(sat)}$<−1.5V (Ic=−500mA, IB=−50mA)							5 *			96	2SD1587 とコンプリ
〃 1097	〃	PA. SW	Si. E	−80	−60	−7A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−60	40〜200	−1	−3A	$V_{CE(sat)}$<−0.5V $V_{BE(sat)}$<−1V (Ic=−5A, IB=−0.5A)										96	2SD1588 とコンプリ
〃 1098	〃	〃	〃	−100	−100	∓5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−100	2000〜20000	−2	−2A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−2A, IB=−2mA)										96	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1099	〃	〃	〃	−100	−100	−8A	25W (Tc=25°C)	150			6000	−2	−3A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−3A, IB=−3mA)										96	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1100	〃	〃	〃	−100	−100	∓10A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	6000	−2	−10A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2.2V (Ic=−10A, IB=−25mA)										96	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1101	日立	AF. PA	Si. T	−60	−60	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−60	5000	−3	−2A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−2A, IB=−4mA)										268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1102	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	5000	−3	−2A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−2A, IB=−4mA)										268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1103	〃	〃	〃	−60	−60	−8A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−60	5000	−3	−4A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−4A, IB=−8mA)										268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1104	〃	〃	〃	−80	−80	−8A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	5000	−3	−4A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−4A, IB=−8mA)										268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1105	〃	〃	〃	−120	−120	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−1.5A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−1.5A, IB=−3mA)										268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1106	〃	〃	〃	−120	−120	−6A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−3A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−3A, IB=−6mA)										268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1107	〃	〃	〃	−120	−120	−10A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−5A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−5A, IB=−10mA)										268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1108	松下	〃	Si. TP	−120	−120	−8A	50W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−4A	$V_{CE(sat)}$<−1.5V $V_{BE(sat)}$<−2V (Ic=−4A, IB=−8mA)										364	ダーリントン
〃 1109	日立	〃	Si. E	−160	−160	−100	1.25W	150	−10	−160	140	−5	−10	−5	10					140 *	5.5		160	2SD1609 とコンプリ
〃 1110	〃	〃	〃	−200	−200	−100	1.25W	150	−10	−160	140	−5	−10	−5	10					140 *	5.5		160	2SD1610 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SB1111	日電	PA. SW	Si. E	−60±10	−60±10	∓2A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−40	2000～30000	−2	−1A			t_{on}=0.1μs, t_f=0.5μs t_{stg}=1.5μs							225	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1112	日立	AF. PA	〃	−120	−120	−6A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−3A										390	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1113	〃	〃	Si. T	−120	−120	−8A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−4A										390	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1114	日電	〃	Si. E	−20	−20	−2A	2 W (セラミック基板使用)	150	−0.1	−16	350	−2	−100	−10	50					180 *	60		336	2SD1614とコンプリ
〃 1115	〃	〃	〃	−60	−50	−1A	2 W (セラミック基板使用)	150	−0.1	−60	340	−2	−100	−2	100					120 *	25		336	2SD1615とコンプリ ○
〃 1116	〃	PA. SW	〃	−60	−50	−1A	750	150	−0.1	−60	135～600	−2	−100	−2	100					120 *	25		138	2SD1616とコンプリ ○
〃 1117	〃	AF. PA	〃	−30	−25	−3A	1 W	150	−0.1	−30	135～600	−5	−1A	−5	1 A					280 *	90		278	2SD1617とコンプリ
〃 1118	三洋	AF	Si. EP	−20	−15	−700	500	150	−1	−15	300	−2	−50										336	
〃 1119	〃	〃	〃	−25	−20	−1A	500	150	−1	−20	150	−2	−50										336	
〃 1120	〃	〃	〃	−20	−10	−2.5A	500	150	−1	−20	230	−2	−500										336	
〃 1121	〃	〃	〃	−30	−25	−2A	500	150	−0.1	−20	180	−2	−100										336	
〃 1122	〃	〃	〃	−60	−50	−1A	500	150	−1	−50	150	−2	−50										336	
〃 1123	〃	〃	〃	−60	−50	−2A	500	150	−0.1	−50	200	−2	−100										336	
〃 1124	〃	〃	〃	−60	−50	−3A	500	150	−1	−40	180	−2	−100										336	
〃 1125	〃	〃	〃	−80	−50	−700	500	150	−0.1	−40	25000	−2	−50										336	ダーリントン
〃 1126	〃	〃	〃	−80	−50	−1.5A	500	150	−0.1	−40	25000	−2	−500										336	ダーリントン
〃 1127	〃	〃	〃	−25	−20	−5A	10W (Tc=25°C)	150	−0.5	−20	250	−2	−500	−5	200					320 *	60		296	
★ 〃 1128	東芝	SW	Si. E	−50	−50	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−40	5000	−2	−1A										384	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1129	日電	AF. PA. SW	〃	−80	−60	∓1.5A	1 W	150	−10	−80	10000	−2	−1A										278	ダーリントン
〃 1130	ローム	AF. PA	Si. EP	−120	−120	−1.5A	1 W	135	−1	−100	180	−5	−100	−5	100					50 *	30		383	
〃 1131	〃	AF	〃	−25	−20	−5A	1 W	150	−0.5	−20	200	−2	−500	−5	200					320 *	60		294	
〃 1132	〃	AF. PA	〃	−40	−32	−1A	500	150	−0.5	−20	180	−3	−100	−5	50					150 *	20		336	
〃 1133	三洋	PA	〃	−60	−60	−3A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−20	150	−2	−1A	−5	500					40 *	110		388	
〃 1134	〃	〃	〃	−60	−50	−5A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−40	150	−2	−1A										388	
〃 1135	〃	〃	〃	−60	−50	−7A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	150	−2	−1A	−5	1 A					10 *			388	2SD1668とコンプリ
〃 1136	〃	〃	〃	−60	−50	−12A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	150	−2	−1A										388	
〃 1137	日電	SW	Si. E	−100	−100	∓10A	65W (Tc=25°C)	150	−10	−100	6000	−2	−10A			t_{on}= 1 μs, t_f= 2 μs t_{stg}= 5 μs							404	ダンパ内蔵ダーリントン
★ 〃 1138																								
★ 〃 1139																								
〃 1140	三洋	PA	Si. EP	−25	−20	−5A	1.3W	150	−0.5	−20	200	−2	−500										389	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ic}(real)* (Ω)	外形	備考
2SB1141	三洋	PA	Si. EP	−20	−18	−1.2A	1.3W	150	−0.1	−15	200	−2	−100										389	
〃 1142	〃	〃	〃	−60	−50	−2.5A	1.3W	150	−0.1	−50	200	−2	−100										389	
〃 1143	〃	〃	〃	−60	−50	−4A	1.3W	150	−1	−40	200	−2	−100										389	
〃 1144	〃	〃	〃	−120	−100	−1.5A	1.3W	150	−0.1	−100	200	−5	−100										389	
〃 1145	日立	AF. PA	Si. T	−120	−120	−3A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−1.5A			t_{on}=0.8μs, t_f=1.5μs t_{stg}=3μs							391	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1146	〃	〃	Si. E	−120	−120	−6A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−3A			t_{on}=1μs, t_f=1μs t_{stg}=2μs							391	〃
〃 1147	〃	〃	Si. T	−120	−120	−8A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−4A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.5μs t_{stg}=1.6μs							391	〃
〃 1148	松下	〃	Si. EP	−40	−20	−10A	15W (Tc=25°C)	150	−50	−40	140	−2	−3A										392	
〃 1149	日電	〃	Si. E	−100	−100	∓3A	1.3W	150	−1	−80	10000	−2	−1.5A										225	
〃 1150	〃	〃	〃	−60±10	−60±10	∓3A	1.3W	150	−1	−40	10000	−2	−1.5A										225	
〃 1151	〃	〃	〃	−60	−60	−5A	20W (Tc=25°C)	150	−10	−50	200	−1	−2A			t_{on}=0.15μs, t_f=0.18μs t_{stg}=0.78μs							225	2SD1691とコンプリ
〃 1152	松下	〃	Si. TP	−160	−160	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−160	110	−5	−1A										365	
〃 1153	〃	〃	Si. EP	−170	−170	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−50	−170	110	−5	−1A										393	
〃 1154	〃	〃	〃	−130	−80	−10A	70W (Tc=25°C)	150	−10	−100	120	−2	−3A										82	2SD1705とコンプリ
〃 1155	〃	〃	〃	−130	−80	−15A	80W (Tc=25°C)	150	−10	−100	120	−2	−3A										82	2SD1706とコンプリ
〃 1156	〃	〃	〃	−130	−80	−20A	100W (Tc=25°C)	150	−10	−100	120	−2	−3A										82	2SD1707とコンプリ
〃 1157	〃	〃	〃	−100	−100	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−50	−100	100	−5	−1A										82	2SD1712とコンプリ
〃 1158	〃	〃	〃	−120	−120	−6A	70W (Tc=25°C)	150	−50	−120	100	−5	−1A										82	2SD1713とコンプリ
〃 1159	〃	〃	〃	−140	−140	−7A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−140	100	−5	−1A										82	2SD1714とコンプリ
〃 1160	〃	〃	〃	−150	−150	−9A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−150	100	−5	−1A										82	2SD1715とコンプリ
〃 1161	〃	〃	〃	−160	−160	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−160	130	−5	−1A										82	2SD1716とコンプリ
〃 1162	〃	〃	〃	−160	−160	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−160	130	−5	−1A										393	
〃 1163	〃	〃	〃	−170	−170	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−50	−170	130	−5	−1A										393	
〃 1164	日電	〃	Si. E	−60	−50	−2A	1W	150	−0.1	−60	300	−2	−100										278	
〃 1165	三洋	〃	Si. EP	−60	−50	−5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−40	200	−2	−500										398	
〃 1166	〃	〃	〃	−60	−50	−8A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−40	200	−2	−500										398	
〃 1167	〃	〃	〃	−120	−100	−3A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−100	200	−5	−500										398	
〃 1168	〃	〃	〃	−120	−100	−4A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−100	200	−5	−500										398	
〃 1169	松下	〃	〃	−60	−60	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−200	−60	100	−4	−1A										392	
〃 1170	〃	〃	〃	−60	−60	−2A	15W (Tc=25°C)	150	−200	−60	100	−4	−1A										392	2SD1751とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SB1171	松下	AF. PA	Si. EP	−200	−150	−2A	15W (Tc=25°C)	150	−50	−200	130	−10	−150										392	2SD1741 とコンプリ
〃 1172	〃	〃	〃	−60	−60	−3A	15W (Tc=25°C)	150	−200	−60	150	−4	−1A										392	2SD1742 とコンプリ
〃 1173	〃	〃	〃	−60	−60	−4A	15W (Tc=25°C)	150	−400	−60	120	−4	−1A										392	2SD1745 とコンプリ
〃 1174	〃	〃	〃	−130	−80	−3A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−100	150	−2	−500										392	2SD1744 とコンプリ
〃 1175	〃	〃	〃	−130	−80	−4A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−100	150	−2	−1A										392	2SD1745 とコンプリ
〃 1176	〃	〃	〃	−130	−80	−5A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−100	150	−2	−2A										392	2SD1746 とコンプリ
〃 1177	〃	〃	〃	−130	−80	−7A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−100	150	−2	−3A										392	2SD1747 とコンプリ
〃 1178	〃	〃	〃	−60	−60	−2A	15W (Tc=25°C)	150	1 mA	−60	5000	−4	−2A										392	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1179	〃	〃	〃	−60	−60	−4A	15W (Tc=25°C)	150	−200	−60	5000	−4	−3A										392	〃
〃 1180	〃	〃	〃	−60	−60	−8A	15W (Tc=25°C)	150	−100	−60	5000	−3	−4A										392	〃
〃 1181	ローム	〃	〃	−80	−80	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−60	180	−3	−100							100*	25		403	
〃 1182	〃	〃	〃	−40	−32	−2A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−20	180	−5	−500							100*	50		403	
〃 1183	〃	〃	〃	−40	−40	−2A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−24	20000	−3	−500								11		403	
〃 1184	〃	〃	〃	−60	−50	−3A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−40	180	−3	−500							70*	50		403	
〃 1185	〃	〃	〃	−60	−50	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−40	120	−3	−500	−5	500					70*	50		405	2SD1762 とコンプリ
〃 1186	〃	〃	〃	−120	−120	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−100	120	−5	−100	−5	100					50*	30		405	2SD1763 とコンプリ ○
〃 1187	〃	〃	〃	−80	−60	−3A	35W (Tc=25°C)	150	−10	−50	120	−5	−500										405	
〃 1188	〃	〃	〃	−40	−32	−2A	500	150	−1	−20	18	−5	−500										336	
〃 1189	〃	〃	〃	−80	−80	−700	500	150	−0.5	−50	180	−3	−100	−10	50					100*	14		336	
〃 1190	松下	〃	〃	−200	−150	−1A	25W (Tc=25°C)	150	−50	−200	120	−10	−100										268	
〃 1191	〃	〃	〃	−200	−150	−1A	25W (Tc=25°C)	150	−50	−200	120	−10	−100										363	2SD1771 とコンプリ
〃 1192	〃	〃	〃	−200	−150	−1A	25W (Tc=25°C)	150	−50	−200	120	−10	−100										364	
〃 1193	〃	〃	〃	−120	−120	−8A	45W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−4A										364	ダーリントン
〃 1194	〃	〃	〃	−100	−100	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−100	5000	−3	−3A			t_{on} < 3 μs, t_f < 3 μs t_{stg} < 5 μs							364	〃
〃 1195	〃	〃	〃	−100	−100	−8A	50W (Tc=25°C)	150	−100	−100	5000	−3	−5A			〃							364	〃
〃 1196	日立	〃	Si. T	−70	−50	−4A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−50	200	−4	−1A										391	
〃 1197	ローム	〃	Si. EP	−40	−32	−800	200	125	−0.5	−20	180	−3	−100	−5	50					150*	20		176	
〃 1198	〃	〃	〃	−80	−80	−500	200	125	−0.5	−50	180	−3	−100	−10	50					100*	14		176	
〃 1199	〃	〃	〃	−15	−15	−1A	300	125	−0.5	−12	100	−3	−100										235	
★ 〃 1200																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SB1201	三洋	SW	Si.EP	−60	−50	−2A	15W (Tc=25°C)	150	−0.1	−50	250	−2	−100	−10	50					150*	22		411	2SD1801 とコンプリ
〃 1202	〃	〃	〃	−60	−50	−3A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−40	250	−2	−100	−10	50					150*	39		411	2SD1802 とコンプリ
〃 1203	〃	〃	〃	−60	−50	−5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−40	150	−2	−500	−5	1A					130*	60		411	2SD1803 とコンプリ
〃 1204	〃	〃	〃	−60	−50	−8A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−40	200	−2	−500	−5	1A					130*	95		411	2SD1804 とコンプリ
〃 1205	〃	〃	〃	−25	−20	−5A	10W (Tc=25°C)	150	−0.5	−20	200	−2	−500	−5	200					320*	60		411	
〃 1206	松下	AF	〃	−30	−25	−100	300	125	−1	−10	250	−10	−2										376	
〃 1207	〃	〃	〃	−15	−10	−500	300	125	−0.1	−10	125	−2	−500										376	
〃 1208	〃	〃	〃	−20	−20	−2A	1W (放熱板付)	150	−1	−20	250	−2	−500										336	
〃 1209	〃	〃	〃	−400	−400	−100	1W (放熱板付)	150	−100	−400	140	−5	−30										151	
〃 1210	ローム	AF.PA	〃	−20	−10	−2A	500	150	−0.5	−16	200	−3	−100	−5	500					80*	40		138	2SD1810 とコンプリ
〃 1211	〃	〃	〃	−20	−20	−2A	500	150	−0.5	−16	200	−3	−100	−5	500					80*	40		336	
〃 1212	〃	〃	〃	−160	−160	−1.5A	900	150	−1	−120	120	−5	−100										294	2SD1812 とコンプリ
〃 1213	日立	〃	Si.T	−120	−120	−10A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−5A										391	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1214	三洋	AF	Si.EP	−80	−60	−3A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−60	5000	−2	−1A										411	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1215	〃	SW	〃	−120	−100	−3A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−100	200	−5	−500			t_{on}<0.3μs, t_f<0.15μs t_{stg}<2.4μs							411	
〃 1216	〃	〃	〃	−120	−100	−4A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−100	200	−5	−500			t_{on}<0.3μs, t_f<0.15μs t_{stg}<2.7μs							411	
〃 1217	日電	AF.PA	Si.E	−60	−60	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−60	200	−5	−600	−5	1.5A					50*	40		225	2SD1818 とコンプリ
〃 1218	松下	AF	Si.EP	−25	−25	−100	150	150	−0.1	−20	260	−10	−2							80*	2.7		412	2SD1819 とコンプリ ○
〃 1219	〃	〃	〃	−30	−25	−500	150	150	−0.1	−20	170	−10	−150							200*	6		412	2SD1820 とコンプリ ○
〃 1220	〃	〃	〃	−150	−150	−50	150	150	−1	−100	200	−5	−10							200*	200		412	2SD1821 とコンプリ
〃 1221	〃	〃	Si.TP	−250	−200	−70	1W	150	−2	−12	110	−10	−5							80*	5		413	
〃 1222	〃	SW	Si.P	−40	−40	−200	200	150	−0.1	−30	180	−1	−10			t_r<35ns, t_f<75ns t_{stg}<225ns							176	
〃 1223	三洋	AF.PA	Si.EP	−70	−60	−4A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−2A	−5	2A					20*			388	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1224	〃	〃	〃	−70	−60	−7A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−3.5A	−5	3.5A					20*			388	〃
〃 1225	〃	〃	〃	−70	−60	−10A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	5000	−2	−5A	−5	5A					20*			388	〃
〃 1226	〃	〃	〃	−110	−100	−3A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−80	4000	−3	−1.5A	−5	1.5A					20*			388	〃
〃 1227	〃	〃	〃	−110	−100	−5A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−80	4000	−3	−2.5A	−5	2.5A					20*			388	〃
〃 1228	〃	〃	〃	−110	−100	−8A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−80	4000	−3	−4A	−5	4A					20*			388	〃
〃 1229	〃	SW	〃	−60	−50	−2A	750	150	−0.1	−50	200	−2	−100	−10	50	t_{on}<60ns, t_f<30ns t_{stg}<450ns				150*	22		138	2SD1835 とコンプリ
〃 1230	〃	PA	〃	−110	−100	−15A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−100	80	−2	−1.5A										346	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SB1231	三洋	PA	Si.EP	−110	−100	−25A	120W (Tc=25°C)	150	−100	−100	80	−2	−2.5A										346	
〃 1232	〃	〃	〃	−110	−100	−40A	150W (Tc=25°C)	150	−100	−100	80	−2	−4A										346	
〃 1233	松下	AF.PA	〃	−200	−150	−1A	15W (Tc=25°C)	150	−50	−200	150	−10	−100										392	
〃 1234	三洋	AF	〃	−80	−50	−200	200	150	−0.1	−60	20000	−2	−100										176	ダーリントン
〃 1235	〃	〃	〃	−80	−50	−200	300	150	−0.1	−60	20000	−2	−100										92	〃
〃 1236	ローム	AF.PA	〃	−120	−120	−1.5A	1W	135	−1	−100	180	−5	−100	−5	100					50*	30		415	
〃 1237	〃	RF.AF	〃	−40	−32	−1A	1W	135	−0.5	−20	180	−3	−100	−3	1		2.3k	1.1	10.4	150*	20	$C_c r_{bb'}$ 80ps	415	
〃 1238	〃	AF	〃	−80	−80	−700	1W	135	−0.5	−50	180	−3	−100										415	
〃 1239	〃	〃	〃	−40	−40	−2A	1W	135	−1	−24	20000	−3	−500										415	
〃 1240	〃	〃	〃	−40	−32	−2A	1W	135	−1	−20	180	−3	−500										415	
〃 1241	〃	〃	〃	−80	−80	−1A	1W	135	−1	−60	180	−3	−100										415	
〃 1242	〃	〃	〃	−50	−50	−1A	1W	135	−1	−30	180	−3	−100										415	
〃 1243	〃	〃	〃	−60	−50	−3A	1W	135	−1	−40	180	−3	−100										415	
〃 1244	日立	AF.PA	Si.E	−160	−160	−100	900	150	−10	−140	140	−5	−10										251	
〃 1245	〃	〃	〃	−200	−200	−100	900	150	−10	−160	140	−5	−10										251	
〃 1246	三菱	PA	〃	−40	−20	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−25	110	−4	−500										416	
〃 1247	〃	〃	〃	−60	−40	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−25	110	−4	−500										416	
〃 1248	〃	〃	〃	−110	−100	−800	10W (Tc=25°C)	150	−10	−25	110	−4	−300										416	
〃 1249	〃	〃	〃	−130	−120	−800	10W (Tc=25°C)	150	−10	−25	110	−4	−300										416	
〃 1250	松下	AF.PA	Si.EP	−100	−80	−3A	35W (Tc=25°C)	150	−100	−100	15000	−5	−2A										364	ダーリントン
〃 1251	〃	〃	〃	−110	−90	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−110	15000	−5	−3A										364	〃
〃 1252	〃	〃	〃	−120	−100	−5A	45W (Tc=25°C)	150	−100	−120	15000	−5	−4A										364	〃
〃 1253	〃	〃	〃	−130	−110	−6A	50W (Tc=25°C)	150	−100	−130	15000	−5	−5A										82	〃
〃 1254	〃	〃	〃	−160	−140	−7A	70W (Tc=25°C)	150	−100	−160	15000	−5	−6A										82	〃
〃 1255	〃	〃	〃	−160	−140	−8A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−160	15000	−5	−7A										82	〃
〃 1256	ローム	〃	〃	−100	−100	−2A	1.2W	150	−10	−100	2000	−2	−1A								35		294	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1257	サンケン	〃	〃	−60	−60	−4A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−60	4000	−4	−3A										400	〃
〃 1258	〃	PA	〃	−100	−100	−6A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	3000	−4	−3A										400	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1259	〃	〃	〃	−100	−100	−10A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	3000	−4	−5A										400	〃
〃 1260	ローム	AF.PA	〃	−80	−80	−1A	500	150	−0.5	−50	180	−3	−500	−10	50					100*	20		336	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SB1261	日電	AF. PA	Si. E	−60	−60	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−60	200	−2	−600	−5	1.5A					50 *	40		186	
〃 1262	日立	〃	Si. T	−60	−60	−4A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−60	5000	−3	−2A										391	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1263	〃	〃	〃	−60	−60	−8A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−60	5000	−3	−4A										391	〃
〃 1264	松下	AF	Si. EP	−250	−200	−70	600	150	−100	−200	90	−10	−5										151	
〃 1265	〃	〃	〃	−400	−400	−100	1 W (PCB付)	150	−100	−400	160	−5	−30										151	
〃 1266	三洋	AF. PA	Si. TP	−60	−60	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	140	−5	−500	−5	500					8 *	60		418	2SD1902とコンプリ
〃 1267	〃	〃	Si. EP	−60	−30	−8A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	140	−2	−1A	−5	1 A					120 *			418	2SD1903とコンプリ
〃 1268	〃	〃	〃	−60	−50	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	140	−2	−1A	−5	1 A					30 *	100		418	2SD1904とコンプリ
〃 1269	〃	〃	〃	−60	−50	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	140	−2	−1A	−5	1 A					10 *			418	2SD1905とコンプリ
〃 1270	〃	〃	〃	−90	−80	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−80	140	−2	−1A	−5	1 A					20 *			418	2SD1906とコンプリ
〃 1271	〃	〃	〃	−90	−80	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	140	−2	−1A	−5	1 A					20 *			418	2SD1907とコンプリ
〃 1272	ローム	〃	〃	−100	−100	−1.5A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	2000	−2	−1A								35		74	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1273	三洋	PA	〃	−60	−60	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−100	−40	140	−5	−500	−5	500					100 *	60		268	
〃 1274	〃	〃	〃	−60	−60	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−40	140	−5	−500	−5	500					100 *	60		388	2SD1913とコンプリ
〃 1275	ローム	AF. PA	〃	−160	−160	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−120	120	−5	−100							50 *	30		403	
〃 1276	〃	AF. LN	〃	−50	−40	−300	250	125	−0.5	−30	270	−6	−10	−6	1		8.1k	2.9	19.6	100 *	20		415	
〃 1277	〃	PA	〃	−40	−32	−2A	750	135	−1	−20	200	−3	−500	−5	500					100 *	50		415	
〃 1278	〃	AF	〃	−80	−80	−700	750	135	−0.5	−50	200	−3	−100	−10	50					100 *	14		415	
〃 1279	〃	〃	〃	−15	−15	−200	300	125	−0.5	−12	180	−3	−100										415	
〃 1280	日立	AF. PA	Si. T	−120	−120	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−1.5A										391	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1281	〃	〃	〃	−120	−120	−6A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−120	5000	−3	−3A										391	〃
〃 1282	新電元	PA. SW	Si. TP	−100	−100	∓4A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−100	>1500	−3	−1A	−10	400	t_{on} < 1 μs, t_f < 2 μs t_{stg} < 4 μs				50 *			410	〃
〃 1283	〃	〃	〃	−100	−100	−7A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−100	>1500	−3	−3A	−10	700	〃				50 *			410	ダーリントン
〃 1284	〃	〃	〃	−100	−100	−10A	35W (Tc=25°C)	150	−100	−100	>1500	−3	−5A	−10	1 A	〃				50 *			410	〃
〃 1285	〃	〃	〃	−100	−100	−15A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−100	>1500	−3	−10A	−10	1.5A	〃				50 *			119	〃
〃 1286	ローム	AF. PA	Si. EP	−100	−100	−2A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−100	2000	−2	−1A								35		268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1287	〃	〃	〃	−100	−100	−2A	20W (Tc=25°C)	150	−10	−100	2000	−2	−1A										405	〃
〃 1288	松下	PA	Si. EP	−30	−20	−5A	1 W	150	−0.1	−10	160	−2	−2A										413	
〃 1289	ローム	AF. PA	〃	−100	−80	−7A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	120	−5	−1A										268	
〃 1290	〃	〃	〃	−100	−80	−7A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	120	−5	−1A										405	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SB1291	ローム	AF. PA	Si. EP	−80	−60	−5A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−80	120	−5	−1A										268	
〃 1292	〃	〃	〃	−80	−60	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−80	120	−5	−1A										405	
〃 1293	〃	〃	〃	−100	−100	−5A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−100	120	−5	−1A										268	
〃 1294	〃	〃	〃	−100	−100	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−100	120	−5	−1A										405	
〃 1295	三洋	AF	〃	−15	−15	−800	200	150	−0.1	−12	135~600	−2	−50	−2	50					300*	15		176	2SD1935とコンプリ
〃 1296	〃	〃	〃	−15	−15	−800	300	150	−0.1	−12	140~560	−2	−50	−2	50					300*	15		92	2SD1936とコンプリ
〃 1297	松下	〃	〃	−120	−120	−500	1 W	150	−10	−120	160	−10	−150										413	
〃 1298	ローム	〃	〃	−40	−32	−2A	1.2W	150	−0.5	−20	180	−3	−500										294	
〃 1299	松下	AF. PA	〃	−80	−60	−3A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−80	600	−4	−500	−12	200					30*			364	
〃 1300	日電	〃	Si. E	−20	−16	−3A	750	150	−0.1	−20	300	−2	−100										138	
〃 1301	〃	〃	〃	−20	−16	−3A	400	150	−0.1	−20	300	−2	−100										336	
〃 1302	三洋	SW	Si. EP	−25	−20	−5A	1.3W	150	−0.5	−20	250	−2	−500	−5	200	t_{on}<200ns, t_f<100ns t_{stg}<1 μs				320*	60		336	
〃 1303	〃	AF. PA	〃	−110	−100	−3A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−80	4000	−3	−1.5A										411	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1304	日立	〃	Si. T	−100	−80	−4A	20W (Tc=25°C)	150	−100	−80	110	−5	−1A										391	
〃 1305	ローム	AF	Si. EP	−30	−20	−5A	750	150	−0.5	−20	220	−3	−500										138	
〃 1306	〃	〃	〃	−30	−20	−5A	1.2W	150	−0.5	−20	220	−3	−500										294	
〃 1307	〃	〃	〃	−30	−20	−5A	300	150	−0.5	−20	220	−3	−500										235	
〃 1308	〃	〃	〃	−30	−20	−5A	500	150	−0.5	−20	220	−3	−500										336	
〃 1309	〃	AF. PA	〃	−80	−80	−700	5 W (Tc=25°C)	150	−0.5	−50	180	−3	−100										244	
〃 1310	〃	〃	〃	−40	−40	−2A	5 W (Tc=25°C)	150	−1	−24	10000	−3	−500										244	ダーリントン
〃 1311	〃	〃	〃	−40	−32	−2A	5 W (Tc=25°C)	150	−1	−20	180	−5	−500										244	
〃 1312	〃	PA	〃	−50	−50	−2A	1.2W	150	−0.1	−50	180	−3	−500										294	
〃 1313	〃	〃	〃	−50	−50	−2A	500	150	−0.1	−50	180	−3	−500										336	
〃 1314	三菱	〃	Si. E	−60	−60	−3A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−50	600	−5	−500										349	
〃 1315	日電	AF. PA	〃	−120	−120	−8A	65W (Tc=25°C)	150	−50	−120	140	−5	−1A										404	
〃 1316	ローム	〃	Si. EP	−100	−100	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−10	−100	3000	−2	−1A								35		403	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1317	松下	〃	Si. TP	−180	−180	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−50	−180	130	−5	−1A										393	
〃 1318	日電	〃	Si. E	−100	−100	∓3A	1 W	150	−1	−100	10000	−2	−1.5A										278	
〃 1319	松下	AF	Si. EP	−30	−20	−5A	1 W (Tc=25°C)	150	−0.1	−10	200	−2	−2A										151	
〃 1320	〃	〃	〃	−30	−25	−100	400	150	−1	−20	260	−10	−2										259	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SB1321	松下	AF	Si.EP	−30	−25	−500	600	150	−0.1	−20	170	−10	−10										259	
〃 1322	〃	PA	〃	−30	−25	−1A	600	150	−0.1	−20	170	−10	−500										259	
〃 1323	三洋	AP	〃	−40	−30	−3A	1.5W	150	−1	−30	100	−2	−500	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=160±48Ω, R_{BE}=800±240Ω)									336	ダンパ内蔵
〃 1324	〃	〃	〃	−40	−30	−3A	1.5W	150	−1	−30	100	−2	−500	バイアス抵抗内蔵形 (R_B= 0, R_{BE}=800±240Ω)									336	〃
〃 1325	〃	〃	〃	−30	−20	−4A	1.5W	150	−1	−20	180	−2	−500	バイアス抵抗内蔵形 (R_B= 0, R_{BE}=1.5k±0.45kΩ)									336	〃
〃 1326	ローム	〃	〃	−30	−20	−5A	1 W	150	−0.5	−20	180	−2	−500										415	
〃 1327	三菱	AF. PA	〃	−100	−80	−5A	58.3W (T_C=25°C)	150	−2.5	−50	100	−5	−2.5A			h_{fe}=10 (−5V, 500mA, 10MHz)					230		148	
〃 1328																								
〃 1329																								
〃 1330																								
〃 1331																								
〃 1332																								
〃 1333																								
〃 1334	ローム	AF. PA	Si.EP	−80	−60	−4A	40W (T_C=25°C)	150	−10	−80	120	−5	−1A	−5	500					12 *	100		268	
〃 1335	〃	〃	〃	−80	−60	−4A	30W (T_C=25°C)	150	−10	−80	120	−5	−1A	−5	500					12 *	100		405	
〃 1336																								
〃 1337	ローム	AF. PA	Si.EP	−150	−150	−2A	40W (T_C=25°C)	150	−10	−150	180	−5	−1A										268	
〃 1338	〃	〃	〃	−150	−150	−2A	30W (T_C=25°C)	150	−10	−150	180	−5	−1A										405	
〃 1339	〃	〃	〃	−120	−120	−6A	40W (T_C=25°C)	150	−10	−120	10000	−3	−2A										268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1340	〃	〃	〃	−120	−120	−6A	30W (T_C=25°C)	150	−10	−120	10000	−3	−2A										405	〃
〃 1341	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	40W (T_C=25°C)	150	−100	−80	3000	−3	−2A										268	〃
〃 1342	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	30W (T_C=25°C)	150	−100	−80	3000	−3	−2A										405	〃
〃 1343	〃	〃	〃	−120	−120	−8A	40W (T_C=25°C)	150	−10	−120	10000	−3	−2A										268	ダーリントン
〃 1344	〃	〃	〃	−120	−120	−8A	30W (T_C=25°C)	150	−10	−120	10000	−3	−2A										405	〃
〃 1345	〃	〃	〃	−100	−80	−7A	80W (T_C=25°C)	150	−10	−100	180	−5	−1A										334	
〃 1346	三洋	〃	Si.TP	−60	−60	−3A	30W (T_C=25°C)	150	−100	−40	150	−5	−500										268	
〃 1347	松下	〃	〃	−160	−160	−12A	120W (T_C=25°C)	150	−50	−160	130	−5	−1A										393	
〃 1348	日立	AF	Si.E	−160	−160	−100	400	150	−10	−140	120	−5	−10										138	
〃 1349	〃	〃	〃	−200	−200	−100	400	150	−10	−140	120	−5	−10										138	
〃 1350																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SB1351	サンケン	PA	Si. EP	−60	−60	−12A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−60	5000	−4	−10A										400	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1352	〃	〃	〃	−60	−60	−12A	60W (Tc=25°C)	150	−10	−60	5000	−4	−10A										172	〃
〃 1353	ローム	AF. PA	〃	−120	−120	−1.5A	15W (Tc=25°C)	150	−1	−100	120	−5	−100										165	
〃 1354	〃	〃	〃	−60	−60	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−60	120	−5	−500										165	
〃 1355	〃	〃	〃	−80	−60	−4A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−80	120	−5	−1A										165	
〃 1356	〃	〃	〃	−100	−80	−7A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−100	120	−5	−1A										165	
〃 1357	〃	〃	〃	−60	−50	−3A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−40	120	−3	−500								40		165	
〃 1358	〃	〃	〃	−80	−60	−5A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−80	120	−5	−1A										165	
〃 1359	〃	〃	〃	−100	−100	−2A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−100	3000	−2	−1A										165	ダーリントン
〃 1360	〃	〃	〃	−100	−100	−5A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−100	120	−5	−1A										165	
〃 1361	松下	〃	Si. T	−150	−150	−9A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−150	120	−5	−1A										82	
〃 1362	〃	〃	Si. TP	−150	−150	−9A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−150	130	−5	−1A										365	
〃 1363	日立	〃	Si. T	−400	−360	−100	900	150	−5	−350	100	−20	−20										251	
〃 1364	〃	AF	Si. E	−30	−25	−1A	500	150	−0.1	−20	120	−2	−500										336	
〃 1365	〃	〃	〃	−20	−16	−2A	500	150	−0.1	−16	200	−2	−100										336	
〃 1366	韓国電子	PA. SW	Si. T	−60	−60	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−60	60~200	−5	−500	−5	500	t_{on}=0.4μs, t_f=0.5μs t_{stg}=1.7μs				9 *	150		381	
〃 1367	〃	PA	〃	−100	−100	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−100	40~240	−5	−1A	−5	1 A					5 *	270		381	
〃 1368	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	25W (Tc=25°C)	150	−30	−80	40~240	−5	−500	−5	500					9 *	130		381	
〃 1369	ローム	AF. PA	Si. EP	−60	−60	−3A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−60	120	−5	−500										268	
〃 1370	〃	〃	〃	−60	−60	−3A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−60	120	−5	−500										405	
〃 1371	松下	AF. PA	Si. T	−120	−120	−6A	70W (Tc=25°C)	150	−50	−120	120	−5	−1A										82	
〃 1372	〃	〃	〃	−140	−140	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−50	−140	120	−5	−1A										82	
〃 1373	〃	〃	〃	−160	−160	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−160	120	−5	−1A										365	
〃 1374																								
〃 1375																								
〃 1376	松下	AF	Si. EP	−30	−25	−100	400	150	−1	−20	250	−10	−2										259	
〃 1377	〃	PA	〃	−30	−25	−500	600	150	−0.1	−20	160	−10	−10										259	
〃 1378	〃	AF	〃	−25	−20	−500	400	150	−0.1	200													259	
〃 1379																								
〃 1380																								

このページは空白です.

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC 11	東芝	SW	Ge. A	18	18S	24	55	75	9	12	44	1	24	6	− 1		t_r=0.06μs, t_f=0.07μs t_s=0.07μs			6	<20	<200	12 A	
★	〃 12	〃	〃	Si.Me	60	60S	250	180	150	10	30	20	10	200				t_d+t_r=0.6μs, t_f=0.5μs t_s=1 μs						84 A	
★	〃 13	〃	〃	Ge. A	18	18S	40	65	75	9	12	48	1	24	6	− 1		t_r=0.32μs, t_f=0.19μs t_s=0.21μs			9			84 A	
★	〃 14	〃	〃	〃	18	18S	40	65	75	9	12	48	1	24	6	− 1		t_r=0.24μs, t_f=0.11μs t_s=0.19μs			15			84 A	
★	〃 15	ソニー	RF	Si.Me	30	30R	50	750	175	1	30	30	5	10	20	− 10	21		5	0.36	150*	2	100*	84 C	
★	〃 16	東芝	SW	Si. P	25	20R	30	250	175	2.5	15	25	1	10				t_r=20ns, t_f=45ns t_s=250ns				<7		49 C	
★	〃 16A	〃	〃	〃	25	20R	50	250	175	1	15	30	1	10										49 C	
★	〃 17	〃	RF	〃	20	20S	50	250	175	2.5	12				6	− 2	30				150*	4	90	49 C	
★	〃 17A	〃	〃	〃	25		30	250	175	1	15				10	− 10	30				150*	4	30	49 C	
★	〃 18	〃	〃	〃	25	20S	30	250	175	0.1	6	12	0.3	0.1	6	− 1	20				50	6	40	49 C	
★	〃 19	〃	SW	〃	40	30R	400	600	150	1	30	50	2	150				t_r=40ns, t_f=120ns t_s=650ns			>70*	30		84 A	
★	〃 20	〃	RF	〃	40		400	600	150	1	30				10	− 10	−0.98*				90	30	25	84 A	
★	〃 21	〃	SW	〃	60	60S	2 A	60 W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	25	10	1 A	30	−300					6*	450		102	
★	〃 22	日電	RF	Si.E	75	50	600	13 W (T_c=25°C)	175	2	50	50	10	150	10	− 50	50	h_{fe}=15dB (f=20MHz)			110*	20	12*	83	
★	〃 23	〃	〃	〃	75	50	500	13 W (T_c=25°C)	175	5	50	50	10	150	10	− 50	50				110*	20	12*	83	
★	〃 24	〃	〃	〃	100	70	500	13 W (T_c=25°C)	175	5	70	50	10	150	10	− 50	50				110*	20	12*	83	
★	〃 25	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Si. Me	60		60	500	150	10	12				12	− 10	50				70	10	70	84 B	
★	〃 26	富士通	RF	〃	60		100	500	150	1	30				10	− 10	50				150	4	70	79	
	〃 27	〃	〃	Si. EP	60		100	650	175	1	30				6	− 1	80				350*	4	50*	84 C	
★	〃 28	〃	〃	〃	40		50	225	150	1	10				10	− 10	30				100*	4	50	84 C	
★	〃 29	〃	〃	〃	40		25	115	150	1	10				10	− 10	30				100*	4	50	84 C	
	〃 30	日電	〃	Si. E	60	30	80	500	150	0.1	30				10	− 10	45	h_{fe} = 23 dB (f = 20 MHz)			280*	4	35	84B	
	〃 31	〃	RF. PA	〃	60	25	200	750	175	0.1	30				10	− 10	35				200*	4	35	84B	
	〃 32	〃	〃	〃	60	25	200	750	175	0.1	30				10	− 10	60				250*	4	40	84B	2SA544 とコンプリ
★	〃 32A	〃	〃	〃	60	25	200	750	175	1	30				10	− 10	60				250*	4	40	84B	
★	〃 33	〃	RF	〃	45	20	150	150	150	0.1	20				10	− 5	55	h_{fe} = 22 dB (f = 20 MHz)			250*	3.5	40	50C	
★	〃 34	松下	SW	Ge. A	20	20X	250	140	75	3	5	30	0.5	200	5	− 3					6*	20		20	
★	〃 35	〃	〃	〃	20	20X	400	140	75	3	5	65	0.5	200	5	− 3					12*	20		20	
★	〃 36	〃	〃	〃	20	20X	400	140	75	3	5	100	0.5	200	5	− 3					20*	20		20	
★	〃 37	日電	RF. IF. Conv Mix. PA	Si. E	40	25	200	200	175	0.1	20				10	− 10	50				200*	4	50	84B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC 38	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc.	Si. E	40	25	200	750	175	0.1	30				10	−10	50				200*	4	50	84B	
	〃 39	富士通	RF	Si. Me	25	15R	50	250	150	0.1	10				6	−1	50				500*	2.3	80*	49C	
	〃 39A	〃	〃	Si. P	25	15R	50	250	150	0.1	10				6	−3	120	NF < 6 dB (f = 1 MHz)			350*	3	65*	49C	
★	〃 40	〃	〃	Si. Me	25		50	250	150	0.1	10				6	−1	50				750*	2.3	80*	49C	
★	〃 41	ソニー	〃	〃	150		5 A	50 W (Tc=25°C)	150	60 mA	150	28	10	1 A	10	−0.5A					20	250	5	102	
★	〃 42	〃	〃	〃	150		5 A	50 W (Tc=25°C)	150	60 mA	150	28	10	1 A	10	−0.5A					20	250	5	102	
★	〃 42A	〃	〃	〃	200	75	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	30	50	40	10	1 A	10	−0.5A					20*	250		102	
★	〃 43	〃	〃	〃	100		5 A	50 W (Tc=25°C)	150	60 mA	100	28	10	1 A	10	−0.5A					20	250	5	102	
★	〃 44	〃	〃	〃	50		5 A	50 W (Tc=25°C)	150	60 mA	50	28	10	1 A	10	−0.5A					20	25	5	102	
★	〃 45	日電	RF	Si. P	45	20	100	500	150	1	30	50	2	10	10	−10	50				160*	4	130*	84B	
★	〃 46	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc. SW	Si. Me	60	40R	300	600	150	0.1	10	50	1	10	6	−1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35*	84C	
★	〃 47	〃	〃	〃	40	25R	300	600	150	1	6	50	1	10	6	−1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35*	84C	
★	〃 48	〃	〃	〃	120	80R	300	600	150	0.1	10	50	1	10	6	−1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35*	84C	
★	〃 49	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Si. E	120	70	300	800	175	0.5	60	60	10	150	10	−50	60				160*	10	17	84B	
★	〃 50	松下	RF. Conv Mix. Osc	Ge. A	20		200	100	75	3	5				6	−1	45				12	20	100	20	
★	〃 51	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc. PA	Si. Me	60	40R	300	1 W	150	0.1	10	50	1	10	6	−1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35	80	
★	〃 52	〃	〃	Si. P	40	35R	100	500	150	0.03	10	50	1	10	6	−1	50	28*	1.5*	0.1*	350*	4	40*	84C	
★	〃 53	〃	RF. IF. Conv Mix. Osc. PA	〃	25	25R	100	600	150	0.5	10	50	1	10	6	−1	50				300*	4	40*	84C	
	〃 54	〃	RF. IF. Conv Mix. Osc. SW	〃	40	35R	100	300	150	0.03	10	50	1	10	6	−1	50	28*	1.5*	0.1*	350*	4	40*	49C	
★	〃 55	〃	RF. IF. Conv Mix. Osc. PA	〃	25	25R	100	360	150	0.5	10	50	1	10	6	−1	50				300*	4	40*	49C	
★	〃 56	〃	RF. Conv Mix. Osc	〃	20		25	200	120	2	12				6	−2	80				180*	2.3	80*	30	
★	〃 57	日電	PA	Si. Me	75	40	500	13 W (Tc=25°C)	175	30	30	30	10	150							110*	22		83	
★	〃 58	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc. PA	〃	60		60	600	175	2	12	50	12	10	12	−10	50				250*	2.5	170	84A	
★	〃 58A	〃	〃	〃	140		60	600	175	2	12	50	12	10	12	−10	50				250*	2.5	170	84A	
★	〃 59	日電	RF	Si. E	120	60	300	800	175	0.5	60	35	10	150	10	−50	35				150*	10	17	84B	
★	〃 60	三洋	〃	Ge. A	20		20	100	85	15	20				6	−1	50				5	15	80	12B	
★	〃 61	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc. SW	Si. Me	30	20R	300	1.2 W	175	1	10	50	1	10	6	−1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35	80	
★	〃 62	日立	SW	Si. P	40	15	50	360	175	0.025	15	100	1	10	10	−10					300*	5.5		49C	
★	〃 63	日電	〃	Si. Me	25	20S	50	300	150	1	15	40	1	10	10	−10					400*	4.5		49C	
★	〃 64	三洋	RF	〃	80		50	600	175	1.5	20				20	−5	50				100*	5	80	84B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC 65	三洋	RF	Si. Me	150	150R	50	600	175	15	150	30	20	5	20	−5	20				200*	<10	<200	84 B	
★	〃 66	〃	〃	〃	150		50	600	175	1.5	20				20	−5	70				130*	5	100	84 B	
	〃 67	日電	SW	Si. E	40	40S	200	360	175	0.1	15	80	1	10				t_{on}<20ns, t_{off}<40ns t_{stg}<20ns						49 C	
	〃 68	〃	SW	〃	40	15	200	360	150	0.1	15	100	1	10	10	−10		t_{on}<20ns, t_{off}<40ns t_{stg}<20ns			400*	3.5	40*	49 C	
★	〃 69	〃	RF	〃	120	60	300	800	175	0.5	60	50	1	150	10	−50	50	h_{fe} = 18dB (f = 20MHz)			160*	10	17	84B	
★	〃 70	東芝	RF	Si. TMe	180		20	800	150	1	30				30	−2	45				125*	1.8	100	84 A	
★	〃 71	〃	SW	Ge. A	18	18S	200	150	85	7	12	100	0.5	100										84 A	
★	〃 72	〃	〃	〃	18	18S	200	150	85	7	12	100	0.5	100										84 A	
★	〃 73	ソニー	RF. Conv. Mix Osc	Ge. G	15		5	30	75	8	15				6	−1	−0.976*	PG = 27 dB (f = 2 MHz)			20	2		18	2S132 2T 73
★	〃 74	東芝	RF	Si. P	30		100	360	175	4	15				6	−2	50				100	2.5	100	84 A	
★	〃 75	ソニー	IF	Ge. G	15		5	30	75	8	15				6	−1	−0.96*	PG = 41 dB (f = 455kHz)			10	2.1		18	2S133 2T 75
★	〃 76	〃	〃	〃	15		5	30	75	8	15				6	−1	−0.96*	PG = 37 dB (f = 455kHz)			10	2.1		18	2S134 2T 76
★	〃 77	〃	〃	〃	15		5	30	75	8	15				6	−1	−0.96*	PG = 32 dB (f = 455kHz)			10	2.1		18	2S135 2T 77
★	〃 78	〃	RF. Conv. Mix Osc	〃	15		5	30	75	2	15				6	−1	−0.98*	33*	2*	0.2*	20	1.5		18	2S136 2T 78
★	〃 79	富士通	〃	Si. Me	15	15R	50	300	175	1	10				6	−1	50				500*	2.3	80*	49 C	
★	〃 80	日電	〃	Si. E	30	15	80	200	175	0.1	20				10	−5	55				200*	3.5	40	50 C	
★	〃 81	三菱	PA	Si. Me	50	40S	5 A	125 W (Tc=25°C)	150	10 mA	50	30	10	1 A	10	−1 A	30				5	300	5	108	
★	〃 82	〃	〃	〃	100	80S	5 A	125 W (Tc=25°C)	150	10 mA	100	30	10	1 A	10	−1 A	30				5	300	5	108	
★	〃 83	〃	〃	〃	150	120S	5 A	125 W (Tc=25°C)	150	10 mA	150	30	10	1 A	10	−1 A	30				5	300	5	108	
★	〃 84	〃	SW	Ge. A	25	15	200	120	85	25	25	40	0.5	20										12 A	
★	〃 85	〃	〃	〃	25	15	400	120	85	25	25	30	0.3	200										12 A	
★	〃 86	〃	〃	〃	25	15	400	120	85	25	25	60	0.3	200										12 A	
★	〃 87	富士通	RF. Conv. Mix Osc. SW. PA	Si. Me	30	30R	100	600	175	1	10	50	1	10	10	−10	50				250*	4	90*	84 C	
★	〃 88	〃	〃	〃	120	100R	100	600	175	1	10	50	1	10	10	−10	50				250*	3	70*	84 C	
★	〃 92	日電	PA	Si. E	100	50	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	0.1	50	35	10	350	10	−350		P_o = 9 W (f = 100MHz)			190*	35	25*	83	
★	〃 93	〃	〃	〃	80	45	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	0.1	50	35	10	350	10	−350		P_o = 9 W (f = 100MHz)			190*	35	25*	83	
★	〃 94	〃	〃	〃	100	50	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	0.1	50	35	10	350	10	−350		P_o = 9 W (f = 100MHz)			190*	35	25*	83	
★	〃 95	東芝	RF. PA	Si. Me	140		100	800	150	1	30				10	−10					140*	10	80	84 A	
★	〃 96	〃	チョッパ	Si. EP	25	15	150	500	175	0.01	15	60			10	−10					150*	17	50	88 A	2素子複合
★	〃 97	日電	RF. SW	Si. E	60	30	1 A	800	175	1	40	60	10	150	10	−50	90	t_{on} = 25ns, t_{off} = 75ns t_s = 50ns			250*	10	17*	84B	

2SC

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SC 98	松下	SW	Si. EP	20	15X	100	300	175	0.1	20	45	0.35	10	2	− 10					350*	< 5		49C		
★	〃 99	〃	〃	〃	20	15X	100	300	175	0.1	20	80	0.35	10	2	− 10					350*	< 5		49C		
★	〃 100	日電	RF. SW	Si. E	40	15	200	150	200	0.025	20	60	1	10	10	− 10	80	$t_d+t_r<40$ns $t_s+t_f<70$ns			400*	35	40*	23		
★	〃 101	東芝	RF	Si. Me	60	60R	2 A	60 W (Tc=25°C)	150	10 mA	20				10	−0.5A	30	h_{fe} = 16 (f = 1 MHz)				350	$C_c r_{bb'}$ 18ns	101		○
★	〃 102	〃	〃	〃	50	40R	7 A	100 W (Tc=25°C)	150	45 mA	50				10	−0.5A	25	h_{fe} = 10 (f = 1 MHz)				850	$C_c r_{bb'}$ 10ns	109		
★	〃 103	〃	SW	Si. P	25	20R	50	250	175	1	15	35	1	10				$t_d+t_r<40$ns $t_s<500$ns, $t_f<60$ns						49C		
★	〃 103A	〃	〃	〃	30	30R	80	250	175	0.2	15	100	1	10										49C		
★	〃 104	〃	RF	〃	25		50	250	175	1	15				10	− 10	32				250*	4	30	49C		
★	〃 104A	〃	〃	〃	30	30R	80	250	175	0.2	15	60	1	10										49C		
★	〃 105	〃	〃	〃	30	30R	80	250	175	0.005	15	35	1	0.1	10	− 10	60				250*	4	30	49C		
★	〃 106	〃	SW. PA	Si. E	60	60R	1.5 A	15 W (Tc=25°C)	150	3 mA	30	20	5	0.5A	12	−200	30				100*	50	7	83		
★	〃 107	〃	〃	〃	60	60R	1 A	15 W (Tc=25°C)	150	3 mA	30	20	5	0.5A	12	−200	30				100*	50	7	83		
★	〃 108	〃	RF. SW	Si. EMe	90	45	600	600	150	1	30	35	2	150	10	− 10					90*	20	55	84 A		○
★	〃 109	〃	SW	〃	50	25	600	600	150	1	30	35	2	150										84 A		○
★	〃 110	日立	RF. PA	Si. Me	40	40S	200	750	175	1	20				6	− 10	80				160*	7	55	84 A		
★	〃 111	〃	〃	〃	50	50S	200	750	175	1	20				6	− 10	50				160*	10	60	84 A		
★	〃 112	〃	SW	〃	40	40S	200	750	175	1	20	50	2	200										84 A		
★	〃 113	〃	〃	〃	50	50S	200	750	175	1	20	50	2	200										84 A		
★	〃 114	〃	〃	〃	50	50S	200	750	175	1	20	50						t_d = 20 ns, t_s = 110ns t_r = 50ns, t_f = 20ns						84 A		
★	〃 115	ソニー	RF	Si. EMe	30	25	50	750	175	3	30	50	5	3	20	− 10	50				200*	3	100*	84B		
★	〃 116	日立	RF. PA	〃	50	25	200	750	175	1	20	40	2	200	6	− 10	40				120*	14	70	84 A		
★	〃 117	〃	SW. PA	Si. TP	75	50	600	13 W (Tc=25°C)	175	5	40	40	15	30	15	− 30	45				112*	15	20	83		
★	〃 118	〃	PA	〃	80	60	600	13 W (Tc=25°C)	175	5	40				15	− 30	45				120*	15	20	83		
★	〃 119	〃	〃	〃	75	50	600	13 W (Tc=25°C)	175	5	40				15	− 30	45				130*	15	20	83		
★	〃 120	日電	RF	Si. E	40	25	25	250	150	0.1	10	40	10	0.05	10	− 1	90	27	2	0.1	200*	4	40	84B		
★	〃 121	〃	RF. Conv. Mix Osc	〃	40	25	25	250	175	1	30				10	− 1	40	35*	2*	0.15*	130*	4	30*	84B		
★	〃 122	〃	〃	〃	40	25	25	250	175	1	30				10	− 1	90	35*	2*	0.15*	160*	4	40*	84B		
★	〃 123	〃	〃	〃	40	25	25	250	175	1	30				10	− 1	140	35*	2*	0.1*	180*	4	40*	84B		
★	〃 124	〃	〃	〃	40	25	25	250	175	0.2	30	40	10	0.05	10	− 1	90	35*	2*	0.1*	200*	4	40*	84B		
★	〃 125	ソニー	RF. SW	Si. EMe	100	100	50	750	175	3	30	50	5	3	20	− 10	50				200*	3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	84C		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC126	ソニー	RF. SW	Si. EMe	140	140	50	750	175	3	30	50	5	3	20	−10	50				200*	3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	84C	
★	〃 127	日電	RF. Conv. Mix Osc	Si. E	20		25	200	175	2	15				10	−1	150				200*	4	40*	84B	
★	〃 128	松下	SW	Ge. A	30	25X	200	150	85	3	5	40	0.5	100	5	−3					7*	9		84A	
★	〃 129	〃	〃	〃	25	20X	200	150	85	3	5	60	0.5	100	5	−3					10*	9		84A	
	〃 130	富士通	RF. Conv. Mix Osc. PA	Si. EP	60	50R	1A	20W (T_c=25°C)	175	0.1	10	40	10	20	10	−20	40				160*	15	35*	83	
	〃 131	〃	SW	〃	40	30R	300	350	175	0.05	10	60	1	10				t_r = 8 ns, t_f = 20ns t_s = 20ns						49C	
	〃 132	〃	〃	〃	20	20R	300	350	175	0.05	10	60	1	10				t_r = 8 ns, t_f = 20ns t_s = 20ns						49C	
	〃 133	〃	〃	〃	20	20R	300	350	175	0.05	10	60	1	10				t_r = 8 ns, t_f = 20ns t_s = 20ns						49C	
	〃 134	〃	〃	〃	40	30R	300	350	175	0.02	10	60	1	10				t_r = 10ns, t_f = 25ns t_s = 100ns						49C	
	〃 135	〃	〃	〃	20	20R	300	350	175	0.02	10	60	1	10				t_r = 10ns, t_f = 25ns t_s = 100ns						49C	
	〃 136	〃	〃	〃	80	60R	300	350	175	0.02	10	60	1	10				t_r = 10ns, t_f = 25ns t_s = 100ns						49C	
	〃 137	〃	〃	〃	25	25R	300	350	175	0.05	10	50	1	10										49C	
	〃 138	日電	RF. PA	Si. E	60	30	500	800	175	1	40	50	10	30	10	−30	50	h_{fe} = 12dB (f = 100MHz)			400*	4	40*	85B	
	〃 138A	〃	〃	〃	60		500	800	175						10	−30	50	h_{fe} = 12dB (f = 100MHz)			400*	4	40*	85B	
	〃 139	〃	〃	〃	60	30	500	800	175	2	40				10	−30	50				400*	4	40*	85B	
★	〃 140	ソニー	RF	Si. EMe	60		1A	1.7W	175	12	30				10	−50	−0.97*				150*	13	20*	84C	
	〃 141	沖	〃	Si. EP	20		200	360	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	95				450*	4	70*	49C	
	〃 142	〃	RF. SW	〃	30	14	200	360	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	95	t_d = 12ns, t_{sig} = 10ns t_r = 16ns, t_{off} = 32ns			450*	4	70*	49C	
★	〃 143	〃	〃	〃	40	18	200	360	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	95	t_d = 12ns, t_{sig} = 10ns t_r = 16ns, t_{off} = 32ns			450*	4	70*	49C	
	〃 144	〃	〃	〃	50	25	200	360	175	0.1	15	65	1	10	10	−10	85	t_d = 12ns, t_{sig} = 15ns t_r = 16ns, t_{off} = 32ns			450*	3	70*	49C	
	〃 144A	〃	〃	〃	60	30	200	360	175	0.1	15	65	1	10	10	−10	85	t_d = 12ns, t_{sig} = 15ns t_r = 16ns, t_{off} = 32ns			450*	3	70*	49C	
★	〃 145	〃	RF	〃	30	16	200	360	175	0.1	15				10	−10	70				500*	3	70*	49C	
★	〃 146	〃	〃	〃	50		200	360	175	0.1	15				10	−10	80				500*	3	70*	49C	
★	〃 146A	〃	〃	〃	60	30	200	360	175	0.1	15				10	−10	80				500*	3	70*	49C	
★	〃 147	ソニー	〃	Si. EMe	30		1A	750	175	5	30	50	4	100	10	−50	−0.96*				120*	12	20*	84C	
★	〃 149	日電	RF. IF. Conv Osc	Si. E	120	80R	300	800	175	10	60	45	10	150	10	−50	45				160*	14	45*	84B	
★	〃 150	日立	RF	〃	20		100	750	175	1	20				6	−10					80*	7	70	84B	
	〃 151	〃	〃	〃	40	25	100	750	175	1	40	20~120	6	10	6	−10					>40*	7	70	84B	
	〃 152	〃	〃	〃	60	25	100	750	175	1	60	20~120	6	10	6	−10					>40*	7	70	84B	
★	〃 153	〃	〃	〃	120	70	100	750	175	1	120	65	5	50	5	−10	40				140*	6	80	84B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC154	日立	RF	Si.T	120	120	100	750	175	0.1	20	35~200	6	10	10	−10					>40*	<8	<120	84B	
★	〃 154A	〃	〃	〃	150	110	100	750	175	10	150				10	−10	60				150*	2.5	<120	84B	
★	〃 155	富士通	RF.Conv.Mix Osc	Si.P	20	20	25	100	125	2	12				6	−2	35				200*	2	60*	35	
★	〃 156	〃	〃	〃	20	20	25	100	125	2	12				6	−2	50				200*	2	80*	35	
★	〃 157	日立	RF	Si.GD	20	20	20	125	150	1	12				6	−2	30				25	3.5	80	84A	
★	〃 158	〃	〃	〃	20	20	20	125	150	1	12				6	−2	40				40	3.5	80	84A	
★	〃 159	〃	〃	〃	20	20	20	125	150	1	12				6	−2	50				60	3.5	80	84A	
★	〃 160	〃	〃	〃	20	20	20	125	150	1	12				6	−2	60				100	3.5	80	84A	
★	〃 161	東芝	SW.PA	Si.Me	60	40R	4A	50 W (T_C=25°C)	150	2mA	30	25	5	3A	10	−200					30*	350	50	102	
★	〃 162	沖	RF	Si.EP	30	16	250	500	175	0.1	15	60	1	50	10	−20	90				500*	3.5	90*	84A	
	〃 163	〃	〃	〃	50	25	250	500	175	0.1	15	60	1	50	10	−20	90				500*	3.3	90*	84A	
	〃 164	〃	〃	〃	60	30	250	500	175	0.1	15	60	1	50	10	−20	90				500*	3.2	90*	84A	
	〃 165	〃	〃	〃	60	30	250	500	175	0.1	15	60	1	50	10	−20	90				500*	3.3	90*	84A	
★	〃 166	日立	RF.SW	Si.GD	30	30	30	200	175	0.1	20	80	12	3	12	−3					16	13	90*	49C	
★	〃 167	〃	〃	〃	55	45	30	200	175	0.1	20	80	12	3	12	−3					16	13	90*	49C	
★	〃 170	富士通	RF.PA	Si.P	25	20R	50	110	175	0.5	20	40	1	10	6	−10	60				250*	5	50	49C	
★	〃 171	〃	〃	〃	25	20R	50	200	175	0.5	20	30	6	0.1	6	−10	60				250*	5	50	49C	
	〃 172	〃	〃	〃	25		50	300	175	0.1	20	30	6	0.1	6	−10	60				350*	5	50	49C	
★	〃 172A	〃	〃	〃	40	20R	50	360	200	0.025	20				6	−10	60				350*	5	50	49C	
★	〃 173	ソニー	RF.Conv.Mix Osc	Ge.G	15	15R	5	30	75	8	15				6	−1	−0.976*				20	2		7	
	〃 174	富士通	〃	Si.P	30		25	200	175	1	12				6	−2	45				170*	1.5	65*	50C	
	〃 174A	〃	〃	〃	60		25	200	175	1	30				6	−2	45				200*	1.5	65*	50C	
★	〃 175	ソニー	IF	Ge.G	15	15R	5	30	75	8	15				6	−1	−0.96*				10	2.1		7	
★	〃 176	〃	〃	〃	15	15R	5	30	75	8	15				6	−1	−0.96*				10	2.1		7	
★	〃 177	〃	〃	〃	15	15R	5	30	75	8	15				6	−1	−0.96*				10	2.1		7	
★	〃 178	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	15	15R	5	30	75	2	15				6	−1	−0.98*	33*	2*	0.2*	20	1.5		7	
★	〃 179	日立	SW	Ge.A	25	15	400	120	85	8	12	40	0.2	20	6	−1		t_r=0.4 μs, t_s=0.25μs	t=0.2 μs		3	25	300	12A	
★	〃 180	〃	〃	〃	25	15	400	120	85	8	12	35	0.3	200	6	−1		t_r=0.3 μs, t_s=0.25μs	t=0.15μs		5	25	250	12A	
★	〃 181	〃	〃	〃	25	12	400	120	85	8	12	60	0.3	200	6	−1		t_r=0.25μs, t_s=0.25μs	t=0.13μs		10	25	250	12A	
★	〃 182	日電	RF.AF.PA	Si.E	25	15	150	150	150	1	20	80	1	20	6	−1	55				90*	6.5	25	23	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SC183	日電	RF.Conv.Mix Osc.AF	Si.E	20	18R	30	100	125	0.1	15	75	3	0.5	6	−1	80	2000	0.55	10	150*	1.6	50*	23		○
★	〃 184	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	20	18R	30	100	125	0.1	15				6	−1	80				200*	1.6	50*	23		
★	〃 185	〃	〃	〃	20	18R	30	100	125	0.1	15				6	−1	80				250*	1.6	50*	23		
★	〃 186	富士通	〃	Si.P	20		25	85	120	2	12				6	−2.5	40				200*	4	35	12A		
★	〃 187	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	20	15	25	85	120	2	12				6	−2.5	50				200*	4	50	12A		
★	〃 188	〃	RF.PA	〃	40	25	500	600	175	1	30	40	10	150	6	−10	50				150*	9	35	84B		
★	〃 189	〃	RF.SW.PA	〃	60	40R	500	600	175	1	30	40	10	150	6	−10	50				150*	9	35	84B		
★	〃 190	〃	〃	〃	60	40R	500	600	175	1	30	75	10	150	6	−10	80				180*	9	35	84B		
★	〃 191	ソニー	RF	Si.GD	60		10	250	150	2	60				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	50	3	200	84A		
★	〃 192	〃	〃	〃	60		10	250	150	2	60				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	10	3	200	84A		
★	〃 193	〃	〃	〃	60		10	250	150	2	60				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	30	3	200	84A		
★	〃 194	〃	〃	〃	60		10	250	150	2	60				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	50	3	200	84A		
★	〃 195	〃	〃	〃	30		10	250	150	1	30				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	10	3	200	84A		
★	〃 196	〃	〃	〃	30		10	250	150	1	30				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	30	3	200	84A		
★	〃 197	〃	〃	〃	30		10	250	150	1	30				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	50	3	200	84A		
	〃 198	富士通	RF.PA	Si.EP	50		500	800	175	1	10				10	−20	40				350*	6	50*	85C		○
★	〃 199	東芝	SW	Si.Me	80	45	50	600	175	0.1	15	70	12	3	12	−3	70	h_{fe} = 2 (f = 50 MHz)				2	100	84B		
	〃 200	富士通	RF.Conv.Mix Osc.PA	Si.EP	40		300	650	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	84C		
	〃 201	〃	〃	〃	20		300	650	175	0.1	10				6	−1	60				350*	4	50*	84C		
	〃 202	〃	〃	〃	80		300	650	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	84C		
	〃 203	〃	〃	〃	40		200	350	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	49C		
	〃 204	〃	RF.SW	〃	30	20	200	350	175	0.05	10	60	1	10	6	−2	70	t_r < 20ns, t_f < 50ns t_s < 250ns			250*	4	80*	49C		
	〃 205	〃	RF.Conv.Mix Osc.PA	〃	80		200	350	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	49C		
★	〃 206	〃	〃	Si.P	20		25	200	175	2	12				6	−2	35				200*	2	80*	50C		
	〃 207	〃	〃	〃	20		25	200	175	0.1	12				6	−2	80				800*	1.0	80*	50C		
★	〃 208	〃	〃	〃	20		25	200	175	1	12				6	−2	60				550*	1.2	80*	50C		
★	〃 209	〃	〃	〃	20		25	200	175	1	12				6	−2	40				450*	1.2	80*	50C		
★	〃 210	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	50		500	650	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	35*	84B		
★	〃 211	〃	RF	〃	25		500	650	175	1	10				10	−20	50				150*	15	35*	84B		
★	〃 212	〃	〃	〃	80		500	650	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	35*	84B		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	r_{bb} h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC 213	富士通	RF. PA	Si. P	50		600	1.5 W	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	35*	83	
★	〃 214	〃	〃	〃	25		600	1.5 W	175	1	10				10	−20	50				150*	15	35*	83	
★	〃 215	〃	〃	〃	80		600	1.5 W	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	35*	83	
★	〃 216	〃	SW	〃	50	50R	300	650	175	0.1	10	50	1	50										84 B	
★	〃 217	〃	〃	〃	25	25R	300	650	175	1	10	50	1	50										84 B	
★	〃 218	〃	〃	〃	80	80R	300	650	175	0.1	10	50	1	50										84 B	
★	〃 220	〃	RF	Si. EP	50		700	650	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	25*	84 B	
★	〃 221	〃	〃	〃	25		700	650	175	1	10				10	−20	50				150*	15	25*	84 B	
★	〃 222	〃	〃	〃	80		700	650	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	25*	84 B	
★	〃 223	〃	RF. PA	〃	50	50R	1 A	1.5 W	175	0.1	10				10	−20	20				150*	15	25*	83	
★	〃 224	〃	〃	〃	25	25R	1 A	1.5 W	175	1	10				10	−20	20				150*	15	25*	83	
★	〃 225	〃	〃	〃	80	70R	1 A	1.5 W	175	0.1	10				10	−20	20				150*	15	25*	83	
★	〃 226	〃	SW	〃	50	50R	700	650	175	0.1	10	50	1	100										84 B	
★	〃 227	〃	〃	〃	25	25R	700	650	175	1	10	50	1	100										84 B	
★	〃 228	〃	〃	〃	80	80R	700	650	175	0.1	10	50	1	100										84 B	
★	〃 229	〃	〃	〃	80	80R	1 A	1.5 W	175	0.1	10	50	1	100										83	
	〃 230	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	80		200	350	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	49 C	
	〃 231	〃	SW	Si. EP	50	50R	700	650	175	1	10	40	1	150										84 B	
	〃 232	〃	〃	〃	25	25R	700	650	175	1	10	40	1	150										84 B	
	〃 233	〃	〃	〃	80	80R	700	650	175	1	10	40	1	150										84 B	
	〃 234	〃	RF. PA	〃	100		1.5 A	1.8 W	175	1 mA	30				10	−150	20				140*	35	25*	83	
★	〃 235	〃	〃	〃	100	90	1.5 A	1.5 W	175	1 mA	30				10	−150	20				120*	35	25*	83	
★	〃 236	〃	〃	〃	90		500	1.8 W	175	0.1	10				10	−20	17				100*	15	25*	83	
	〃 237	〃	RF	Si. EP	30		300	350	175	0.05	10				6	−1	80				450*	5	50*	49 C	
	〃 238	〃	RF. AF	〃	40		100	650	175	0.1	10				6	−1	80	30*	3*	0.1*	350*	4	50*	84 B	
	〃 239	〃	SW	〃	50	30R	300	350	175	0.05	10	60	1	10				t_r<20ns, t_f<50ns t_s<100ns						49 C	
★	〃 240	日電	SW	Si. EMe	100	60	5 A	75 W (T_c=25°C)	175	5 mA	100	35	10	1 A	2	−1 A					35			102	
★	〃 241	〃	〃	〃	60	40	5 A	75 W (T_c=25°C)	175	10mA	60	35	10	1 A	10	−1 A		t_d=0.03μs, t_s=1μs t_r=0.47μs, t_f=0.5μs			35			102	
★	〃 242	〃	〃	〃	100	60	5 A	75 W (T_c=25°C)	175	10mA	100	35	10	1 A	10	−1 A		t_d=0.03μs, t_s=1μs t_r=0.47μs, t_f=0.5μs			35			102	
★	〃 243	〃	〃	〃	140	80	5 A	75 W (T_c=25°C)	175	10mA	140	35	10	1 A	10	−1 A		t_d=0.03μs, t_s=1μs t_r=0.47μs, t_f=0.5μs			35			102	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC244	日電	SW	Si.EMe	60	25	5 A	75 W (Tc=25°C)	175	50mA	60	35	10	1 A	10	−1 A		t_d=0.03μs, t_s=1μs t_r=0.47μs, t_f=0.5μs			35			102	
★	〃 245	〃	〃	〃	120	45	5 A	75 W (Tc=25°C)	175	20mA	120	35	10	1 A	10	−1 A		t_d=0.03μs, t_s=1μs t_r=0.47μs, t_f=0.5μs			35			102	
★	〃 246	〃	〃	〃	180	60	5 A	75 W (Tc=25°C)	175	20mA	180	35	10	1 A	10	−1 A		t_d=0.03μs, t_s=1μs t_r=0.47μs, t_f=0.5μs			35			102	
	〃 247	富士通	RF. PA	Si. P	100		100	600	175	1	30				6	− 2	60				150*	3	70*	84 B	
	〃 248	〃	〃	〃	70	50R	50	300	175	1	30				6	−2.5	60				170*	2.5	50	49 C	
	〃 249	〃	〃	〃	70	60R	70	500	175	1	30				6	−2.5	60				170*	2.7	50	84 B	
★	〃 250	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	20		25	60	150	2	12				6	− 2	45				170*	2	65	13 A	
★	〃 251	日電	〃	Si. E	30	15	30	200	150	1	15				6	− 5	50	NF < 6 dB (f = 1 MHz)			900*	1	70*	50 C	
★	〃 251A	〃	〃	〃	30		30	200	150	1	15				6	− 5	50	NF < 6 dB (f = 1 MHz)			900*	1	70*	50 C	
★	〃 252	〃	〃	〃	30	15	30	200	150	1	15				6	− 5	50				900*	1	70*	50 C	
★	〃 253	〃	〃	〃	30	15	30	200	150	1	15				6	− 5	50	NF < 6 dB (f = 70 MHz)			900*	1	70*	50 C	
★	〃 254	沖	RF. PA	Si. EP	50	25	800	650	175	2	40	50	1	150	10	− 50	55				250*	13	20*	84 A	
★	〃 255	〃	〃	〃	80	40	800	650	175	1	40	45	1	150	10	− 50	50				250*	13	20*	84 A	
★	〃 256	〃	〃	〃	90	50	800	650	175	1	40	45	1	150	10	− 50	50				250*	13	20*	84 A	
★	〃 257	〃	〃	〃	50	25	800	800	175	2	40	50	1	150	10	− 50	55				250*	13	20*	91	
★	〃 258	〃	〃	〃	80	40	800	800	175	1	40	45	1	150	10	− 50	50				250*	13	20*	91	
★	〃 259	〃	〃	〃	90	50	800	800	175	1	40	45	1	150	10	− 50	50				250*	13	20*	91	
★	〃 260	〃	PA	〃	30	25	1 A	1.6W	175	2	20	60	10	150	10	− 50	65				280*	15	23*	83	
★	〃 261	〃	〃	〃	60	40	1 A	1.6W	175	1	20	60	10	150	10	− 50	65				280*	14	23*	83	
	〃 262	〃	〃	〃	80	50	1 A	1.6W	175	1	20	60	10	150	10	− 50	65				280*	13	23*	83	
★	〃 263	〃	RF	〃	15		120	100	100	0.4	9				5	− 1	60				200*	3	70*	21	
★	〃 264	〃	RF. SW	〃	30	14	120	100	100	0.1	9	75	1	10	5	− 5	85	t_d=12ns, t_{stg}=10ns t_r=15ns, t_{off}=30ns			400*	3	70*	21	
★	〃 265	〃	〃	〃	40	18	120	100	100	0.1	9	75	1	10	5	− 5	85				400*	3	70*	21	
★	〃 266	日電	RF. AF	Si. E	30	20	30	100	150	0.1	25	75	3	0.5	6	− 1	80	2000	0.55	10	250*	1.6	45	23	
★	〃 267	〃	RF. PA	〃	35	20	200	150	150	1	35	70	1	20	6	− 1	45				90*	6.5	25	23	
★	〃 268	〃	RF. PA. SW	〃	60	60X	30	150	150	5	50	40	1	1	6	− 1	55				150*	1.6	50	23	○
★	〃 269	〃	SW	〃	25	20S	200	150	150	1	15	85	0.5	1				t_{on}<20ns, t_{off}<40ns t_{stg}<20ns						23	
★	〃 270	ソニー	PA	Si. Me	270	75	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	1 mA	50	40	3	2 A	10	−500	56				22*	250	5	102	
★	〃 271	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si. E	25	12	20	100	150	1	12				6	− 2	70	NF < 8 dB (f = 70 MHz)			1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 10 ps	23	
★	〃 272	〃	〃	〃	25	12	20	100	150	1	12				6	− 2	70	NF = 8 dB (f = 900 MHz)			1200*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 3 ps	23	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V_o)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC 273	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si.E	120	120R	50	500	150	1	60				30	−3	50				150*	2.5	25	84B	
★	〃 274	沖																							
★	〃 275	〃																							
★	〃 276	〃																							
★	〃 277	〃																							
★	〃 278	〃																							
★	〃 279	〃																							
★	〃 280	日立	Diff	Si.E	30	20	10	80	125	0.01	20	80	−6	0.1										15	
★	〃 281	〃	RF	Si.EPa	30	20	100	200	175	0.1	20	170	6	10	6	−0.1	50	h_{fe} = 8 (6 V, 10mA, 20MHz)			>80*	7	70	12C	
★	〃 282	〃	SW	〃	30	20	100	350	175	1	20	100	6	10	6	−10					180*	7	60	12A	
★	〃 283	〃	PA	〃	50	20	100	350	175	0.1	20	65	6	10	6	−10	100				180*	7	60	12A	
★	〃 284	〃	SW	〃	70	25	100	350	175	1	20	60	6	10	6	−10					160*	7	60	12A	
★	〃 285	富士通	PA	Si.EP	50		200	500	150	0.1	10				10	−10	60				320*	3.5	80*	84B	
★	〃 285A	〃	RF. PA	〃	50		300	500	150	0.1	10				10	−10	60	KF_2>30dB, KF_3>55dB (15V, 50mA, 1MHz)			500*	3.5	60*	84B	
★	〃 286	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si.E	20		10	100	150	1	12				6	−2	70	PG = 24 dB (f = 100MHz)			900*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 15 ps	23	
★	〃 287	〃	〃	〃	20	12	10	100	150	1	12				6	−2	70	PG = 20 dB (f = 200MHz)			900*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 12 ps	23	○
★	〃 288	〃	〃	〃	30	12	20	100	150	1	12				6	−2	70	P_o = 23 mW (f = 900MHz)			1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 10 ps	23	○
★	〃 289	〃	〃	〃	25	12	20	100	150	1	12				6	−2	70	NF = 9 dB (f = 900MHz)			1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	23	
★	〃 290	〃	PA	〃	70	40	2 A	20 W (T_c=25°C)	175	3 mA	30	35	10	350	10	−350		P_o = 6 W (f = 100MHz)			160*	35	25*	83	
★	〃 291	ソニー	〃	〃	70	40	3 A	1 W	175	3	30	70	2	100	10	−50	70				90*	18	$C_c r_{bb'}$ 50 ps	84C	
★	〃 292	〃	〃	〃	100	60	3 A	1 W	175	3	30	70	2	100	10	−50	70				90*	18	$C_c r_{bb'}$ 50 ps	84C	
★	〃 293	〃	〃	〃	130	80	3 A	1 W	175	3	30	70	2	100	10	−50	70				90*	18	$C_c r_{bb'}$ 50 ps	84C	
	〃 294	日電	Diff	〃	25	12	50	300	175	0.1	10	80	1	1	6	−2		h_{FE1}/h_{FE2} = 0.8～1.0			200*	4.5	40	87B	2素子複合
★	〃 295	〃	Ch	〃	15	10	50	300	175	1	10	50	1	0.2	6	−2					200*	4.5	40	86B	2素子複合
★	〃 296	富士通	RF.Conv.Mix Osc	Si.P	20		25	200	175	1	12				6	−2	80				180*	2.5	100*	50C	
★	〃 297	ソニー	PA	Si.E	70	40	3 A	10 W (T_c=25°C)	175	3	30	70	2	100	10	−50	70				90*	18	$C_c r_{bb'}$ 50 p	97C	
★	〃 298	〃	〃	〃	100	60	3 A	10 W (T_c=25°C)	175	3	30	70	2	100	10	−50	70				90*	18	$C_c r_{bb'}$ 50 ps	97C	
★	〃 299	〃	〃	〃	130	80	3 A	10 W (T_c=25°C)	175	3	30	70	2	100	10	−50	70				90*	18	$C_c r_{bb'}$ 50 ps	97C	
	〃 300	三菱	RF. SW	Si.EP	25	15	100	260	150	0.5	15	85	10	0.1	15	−10					400*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 250ps	49B	
	〃 301	〃	〃	〃	25	15	100	260	150	0.01	15	85	10	0.1	15	−10					400*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 250ps	49B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
	2SC302	三菱	RF. SW	Si. EP	50	20	100	260	150	0.01	30	85	10	0.1	15	−10					400*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 250ps	49B		
★	〃 303	〃	RF. PA	〃	50		500	800	200	50	28	20	28	100	20	−50					200*	10		84B		
★	〃 304	〃	〃	〃	60		500	800	200	10	28	25	28	100	20	−50					220*	10		84B		
★	〃 305	〃	〃	〃	80		500	800	200	0.05	28	30	28	100	20	−50					220*	10		84B		
	〃 306	〃	RF. SW	〃	50	30	500	570	150	0.1	30	85	10	150	10	−30					240*	10	$C_c r_{bb'}$ 300ps	84B		
	〃 307	〃	〃	〃	80	40	500	570	150	0.01	30	85	10	150	10	−30					240*	10	$C_c r_{bb'}$ 300ps	84B		
★	〃 308	〃	〃	〃	100	60	500	800	200	1	90	65	10	150	10	−30					90*	10	30*	84B		
	〃 309	〃	〃	〃	120	80	500	570	150	0.1	90	65	10	150	10	−30					120*	6	$C_c r_{bb'}$ 180ps	84B		
	〃 310	〃	〃	〃	140	100	500	570	150	0.01	90	65	10	150	10	−30					120*	6	$C_c r_{bb'}$ 180ps	84B		
★	〃 311	富士通																								
★	〃 312	〃																								
★	〃 313	日立	RF.Conv.Mix Osc	Si. EP	30	12	50	200	200	0.5	10	40	10	10	10	−10	50				1000*	1	$C_c r_{bb'}$ 10 ps	9		
★	〃 314	〃	PA	Si.TMe	75	60	1.2 A	2 W	175	10	40				4	−100	25				70*	20	27	83		
★	〃 315	〃	〃	〃	75	60	1.2 A	2 W	175	10	40				4	−100	25				80*	20	25	83		
★	〃 316	松下	RF.Conv.Mix Osc. PA	Si. P	45	45	30	300	175	0.01	10				5	−2	300	6500	1.4	32	50*	4.5	80	49C		
★	〃 317	日立	SW	Si. Me	70	50	100	350	175	0.1	20	100	6	10	6	−10		$t_d+t_r<0.08\mu s$, $t_s<0.7\mu s$, $t_f+t_s<0.2\mu s$			240*	4.5	75	12A		○
★	〃 318	ソニー	RF	Si. E	50	30	100	300	175	0.2	25	90	3	1	6	−2		h_{fe} = 4.5dB (f = 100MHz)				3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	49C		○
★	〃 319	日電	RF.Conv.Mix Osc. PA	〃	40	20	300	1.75W (T_c=25°C)	175	0.5	20	40	10	100	10	−30	40	P_o = 1.2W (f = 200MHz)			500*	6.5	40*	84B		
★	〃 320	〃	〃	〃	40	20	500	2.5W (T_c=25°C)	175	0.5	20	40	10	100	10	−30	40	P_o = 2.4W (f = 200MHz)			600*	6.5	40*	84B		
	〃 321	日立	SW.RF	Si.EP	40	15	200	360	175	1	20	35~200	1	10	10	−20	t_{on} = 20ns, t_{off} = 25ns t_{stg} = 10ns				450*	4		49C		
★	〃 322	〃	〃	〃	40	20S	200	360	175	0.25	20	40	1	10	10	−20					450*	4		49C		
★	〃 323	東芝	〃	〃	40	20	100	250	175	1	30	50	1	10										49C		
	〃 324	富士通	RF.Conv.Mix Osc	Si. P	20		25	200	175	2	12				6	−2	70				180*	4.5	60*	49C		
★	〃 325	沖	RF	Si. EP	12	12	50	250	175	0.02	6				5	−5	110				1000*	1.7	90*	50C		
★	〃 326	〃	〃	〃	20	16	50	250	175	0.02	6				5	−5	110				1000*	1.7	90*	50C		
	〃 327	〃	〃	〃	30	20	50	250	175	0.02	6				5	−5	110				1000*	1.7	90*	50C		
	〃 328	〃	〃	〃	30	15	20	200	175	0.2	15				6	−5	60	NF = 2dB (f = 70MHz)			1500	0.65	$C_c r_{bb'}$ 5ps	50C		
	〃 329	〃	〃	〃	30	15	20	200	175	0.2	15				6	−5	60	NF = 1.5dB (f = 70MHz)			1500*	0.65	$C_c r_{bb'}$ 5ps	50C		
★	〃 330	〃	RF. LN	〃	20	15	20	200	175	0.5	15	60	10	10	10	−10	NF = 2.5dB (6V, −3mA, 450MHz)				3500*	0.75	$C_c r_{bb'}$ 2.5ps	128		
★	〃 331	〃	〃	〃	20	15	20	200	175	0.5	15	60	10	10	10	−10	NF = 2.0dB (6V, −3mA, 450MHz)				3500*	0.75	$C_c r_{bb'}$ 1.5ps	128		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC332	沖	RF.SW	Si.EP	30	14	200	150	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	95	t_{on}<40ns, t_{off}<44ns t_s<26ns			450*	3	70*	48C	
★	〃 333	〃	〃	〃	40	18	200	150	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	95	t_{on}<40ns, t_{off}<44ns t_s<26ns			450*	3	70*	48C	
★	〃 334	〃	〃	〃	60	30	200	150	175	0.1	15	65	1	10	10	−10	85	t_{on}<40ns, t_{off}<44ns t_s<26ns			450*	2	70*	48C	
★	〃 335	〃	〃	〃	50	25	200	250	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	100	t_{on}<40ns, t_{off}<44ns t_s<26ns			450*	3	70*	49C	
★	〃 336	〃	〃	〃	60	30	200	250	175	0.1	15	75	1	10	10	−10	100	t_{on}<40ns, t_{off}<44ns t_s<26ns			450*	3	70*	49C	
★	〃 337	〃	RF	Si.P	20	16	20	360	175	0.1	15	73	1	2	5	−1	80				100*	3	50*	49C	
★	〃 338	〃	〃	〃	70	40	20	360	175	0.1	15	73	1	2	5	−1	80				100*	3	50*	49C	
★	〃 339	〃	〃	〃	110	60	20	360	175	0.1	15	73	1	2	5	−1	80				100*	3	50*	49C	
★	〃 340	〃	〃	〃	20	16	20	100	100	0.1	15	170	1	2	5	−1	2200				130*	1.4	60*	21	
★	〃 341	〃	〃	〃	70	40	20	100	100	0.1	15	73	1	2	5	−1	80				120*	1.4	60*	21	
★	〃 342	〃	〃	〃	110	60	20	100	100	0.1	15	73	1	2	5	−1	80				120*	1.4	60*	21	
★	〃 343	〃	RF.SW	Si.EP	35	22	500	600	175	0.4	20	55	1	150	10	−30	70				430*	6.5	45*	84A	
★	〃 344	〃	〃	〃	60	25	500	600	175	0.4	20	55	1	150	10	−30	70				430*	6	45*	84A	
★	〃 345	〃	〃	〃	80	30	500	600	175	0.4	20	55	1	150	10	−30	70				430*	5	45*	84A	
★	〃 346	〃	RF.SW	〃	45	25	700	600	175	1	40	70	1	100	10	−30	75	t_{on}<80ns, t_{off}<70ns t_{stg}<35ns			320*	10	40*	84A	
★	〃 347	〃	〃	〃	60	30	700	600	175	1	40	70	1	100	10	−30	75	t_{on}<80ns, t_{off}<70ns t_{stg}<35ns			320*	10	40*	84A	
	〃 348	〃	〃	〃	60	40	700	600	175	1	40	70	1	100	10	−30	75	t_{on}<80ns, t_{off}<70ns t_{stg}<35ns			320*	7.5	40*	84A	
★	〃 349	〃	〃	〃	90	50	700	600	175	1	40	70	1	100	10	−30	75	t_{on}<80ns, t_{off}<70ns t_{stg}<35ns			320*	7.5	40*	84A	
★	〃 350	日立	RF.AF.LN	Si.Me	30	20	100	200	175	0.01	20	120	6	0.1	6	−1	160	7000	2	25	180*	7	60	12A	
★	〃 351	東芝	RF	Si.P	40		20	200	150	0.5	18				10	−4	50				600*	1.4	15	33	
★	〃 352	ソニー	〃	Si.EP	50	30	100	750	175	0.2	25	90	3	1	6	−2		h_{fe}=4.5dB (f=100MHz)						181	○
★	〃 353	〃	〃	〃	100	60	100	750	175	0.2	25	90	3	1	6	−2		h_{fe}=4.5dB (f=100MHz)						181	○
★	〃 354	富士通	RF.PA	Si.TP	40		1.5A	7 W (T_c=25°C)	200	1	30	100	4	500	4	−100	50				180*	20	10*	84B	
★	〃 355	〃	PA	〃	75		2.5A	15 W (T_c=25°C)	200	1	30	100	4	500	4	−100	50	P_o=3 W (f=150MHz)			180*	20	10*	111	
	〃 356	日電	SW	Si.E	30	15	200	300	175	1	20	60	1	10	10	−10		t_{on}<20ns, t_{off}<40ns t_{stg}<20ns			400*	4.5	50	315	
★	〃 357	〃																							
★	〃 358	〃																							
★	〃 359	〃																							
★	〃 360	東芝	RF	Si.P	30	18	100	250	175	1	15				10	−10	100				150*	5	50	49C	
★	〃 361	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	25		100	200	125	0.5	18	40~160	12	2	6	−2	80				150*	4	90	33	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC362	東芝	RF.Conv.Mix Osc	Si.P	25		100	200	125	0.5	18	70~280	12	2	6	−2	140				150*	4	90	33	
★	〃 363	〃	〃	〃	25		100	200	125	0.5	18	150~500	12	2	6	−2	250				150*	4	90	33	
★	〃 364	〃	RF. Conv Mix. Osc	〃	25		40	200	125	0.5	18				6	−2	400				150*	4	100	33	
★	〃 365																								
	〃 366	東芝	RF. Conv Mix. Osc	Si.E	60	40	400	400	125	0.1	40	70~240	1	100	10	−10	60				>100*	10	50	138	
	〃 367	〃	〃	〃	40	30	400	400	125	0.1	40	70~240	1	100	10	−10	70				>100*	10	50	138	2SA467 とコンプリ
★	〃 368	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	25		100	250	175	0.1	18				10	−1	250				150*	1.5	120	49C	
★	〃 369	〃	〃	〃	18	18	100	200	125	0.1	18				10	−1	250				150*	1.5	120	33	
★	〃 370	〃	〃	〃	30	30	100	200	125	1	18				6	−1	40				150*	2.5	80	33	
★	〃 371	〃	〃	〃	30	18	100	200	125	1	18				6	−1	80				150*	2.5	80	33	
	〃 372	〃	〃	〃	60	50	150	400	125	0.1	60	70~400	1	10	10	−1					200*	2	50	138	2SA495 とコンプリ
	〃 373	〃	〃	〃	60	50	150	400	125	0.1	60	200~400	1	10	10	−1					200*	2	50	138	
★	〃 374	〃	〃	Si.EP	30	25	100	200	125	1	18				6	−1	400				150*	2.5	80	33	
★	〃 375	〃	RF	〃	20	12	50	200	125	0.5	15				10	−8	100				600*	1.5	20	33	
★	〃 376	〃	〃	〃	70	70R	100	200	125	1	18				6	−1	60				150*	2.5	40	33	
★	〃 377	〃	〃	〃	35	30	30	200	125	0.5	18				12	−2	70				150*	2	$C_c r_{bb'}$ 40ps	33	
★	〃 378	〃	RF. Conv. Mix	〃	35	30	30	200	125	0.5	18	40~240	12	2	10	−1					150*	2	$C_c r_{bb'}$ 40ps	33	
★	〃 379	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	30	20	100	200	125	0.5	18				10	−2	70				300*	2	40	33	
	〃 380	〃	RF	〃	35	30	50	300	125	0.1	35	40~240	12	2	10	−1					100~400*	2	$C_c r_{bb'}$ 10~50ps	138	○
★	〃 381	〃	〃	〃	40	30	20	100	125	0.5	18	25~140	6	1	6	−1					250*	2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	33	
	〃 382	〃	〃	Si.P	40	40	50	250	125	0.1	40	>30	10	4	10	−4		PG>32 dB (f=45MHz)			>400*	C_{re} <1.2	$C_c r_{bb'}$ <30ps	138	フォワード AGC
	〃 383	〃	〃	Si.EP	50	45	50	300	125	0.1	50	20~100	12.5	12.5	12.5	−12.5					>300*	0.8~2.0		138	
★	〃 384	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	20	30	50	200	125	0.5	15				6	−1	50				500*	1.4	25	33	
★	〃 385	〃	〃	〃	20		20	200	125	0.5	15				3	−8	80				600*	1.6	20	33	○
★	〃 386	〃	RF. Conv. Mix	〃	20		20	200	125	0.5	15				3	−8	80				500*	1.6	18	33	○
★	〃 387	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	20	12	50	200	125	0.5	15				10	−8	100	P_o=8 mW (f=930MHz)			900*	1.4	15	33	○
★	〃 388	〃	RF. Conv. Mix	〃	20	25	20	200	125	0.5	15				3	−8	80				450*	1.6	18	138	○
★	〃 389	〃	RF	Si.P	20	15	20	150	150	0.1	10				5	−4	50				500*	0.8	10	50C	
★	〃 390	〃	〃	Si.EP	30	20	20	150	150	0.1	10	40~200	10	2	10	−2		NF=2 dB (f=100MHz, 10V, 2mA)			1000*	0.1	$C_c r_{bb'}$ <6 ps	50C	
★	〃 391	〃	〃	〃	20	12	20	150	150	1	10				10	−2	70				1200*	1	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	50C	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC392	東芝	RF	Si.EP	30	20	20	150	150	0.1	15	40~300	10	2	10	−2		NF=4.5dB (f=800MHz)			800*	C_{re} 0.3	$C_c r_{bb'}$ <5 pS	50C	フォワードAGC	○
★	〃 393	〃	〃	〃	20		20	200	150	50	10				5	−4	100	PG=35dB (f=45MHz)						50C		
★	〃 394	〃	RF.Conv.Mix	〃	35	30	100	200	125	0.5	18	40~240	12	2	10	−1					200*	2	$C_c r_{bb'}$ 45pS	33		
★	〃 395	〃	SW	〃	20	12	200	250	175	1	15	50	1	1										49C		○
★	〃 396	〃	RF	〃	30	12	200	250	175	1	15				10	−10	40				450*	3	60	49C		
★	〃 397	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	20	12	50	200	175	0.5	15				10	−8	80				800*	1.9	30	50C		
★	〃 398	〃	RF	〃	20	20	20	200	150	0.05	10	20~200	5	4	10	−4					>250*	$C_c r_{bb'}$ 0.25~0.5	<25	50C	フォワードAGC	
★	〃 399	〃	RF.Conv	〃	20	20	20	200	150	0.05	10	20~200	5	4	10	−4					>250*	$C_c r_{bb'}$ 0.25~0.5	<25	50C	フォワードAGC	
	〃 400	〃	RF. SW	Si. E	30	20	100	250	175	0.5	15	60~350	1	10	10	−10	80	300	2	150	300*	4	40	49C	2SA500とコンプリ	
★	〃 401	ソニー	RF.Conv.Mix Osc. SW	〃	50	25	100	100	120	0.2	25	90	3	1	6	−1	110	t_r<0.06μs, t_f<0.15μs t_s<0.5μs			140*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 80pS	38		
★	〃 402	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	50		100	100	120	0.2	25	90	3	1	6	−1	110				140*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 80pS	38		○
★	〃 403	〃	〃	〃	50		100	100	120	0.2	25	60	3	1	6	−1	75				140*	2.2	$C_c r_{bb'}$ 50pS	38		○
★	〃 404	〃	RF	〃	50	25	50	100	120	0.2	25	90	3	1	6	−1	120				140*	2.2	$C_c r_{bb'}$ 80pS	38		
★	〃 405	三菱	SW	Ge. A	25	20R	200	150	100	10	25	60	1	100										69	2SA458とコンプリ	
★	〃 406	〃	〃	〃	25	20R	200	150	100	10	25	120	1	100										69	2SA459とコンプリ	
	〃 407	新電元	〃	Si. DB	150	100	10A	100W (Tc=25°C)	150	50mA	150	20	5	5A	10	2A		t_r<1μs, t_f<1μs t_s<4μs			$f_{\alpha e}$ 0.4	300		102		
	〃 408	〃	〃	〃	150	100	10A	100W (Tc=25°C)	150	50mA	150	40	5	5A	10	2A		t_r<1μs, t_f<1μs t_s<4μs			$f_{\alpha e}$ 0.4	300		102		
	〃 409	〃	〃	〃	200	140	10A	100W (Tc=25°C)	150	20mA	200	20	5	5A	10	2A		t_r<1μs, t_f<1μs t_s<4μs			$f_{\alpha e}$ 0.4	300		102		
	〃 410	〃	〃	〃	200	140	10A	100W (Tc=25°C)	150	20mA	200	40	5	5A	10	2A		t_r<1μs, t_f<1μs t_s<4μs			$f_{\alpha e}$ 0.4	300		102		○
	〃 411	〃	〃	〃	300	200	10A	100W (Tc=25°C)	150	5mA	300	20	5	5A	10	2A		t_r<1μs, t_f<1μs t_s<4μs			$f_{\alpha e}$ 0.4	300		102		
	〃 412	〃	〃	〃	300	200	10A	100W (Tc=25°C)	150	5mA	300	40	5	5A	10	2A		t_r<1μs, t_f<1μs t_s<4μs			$f_{\alpha e}$ 0.4	300		102		
★	〃 413	沖	PA. SW	Si. EP	60	40	1.5A	20W (Tc=25°C)	175	10	50	50	10	150	10	−100	60				180*	20	10*	83		
★	〃 414	〃	〃	〃	90	60	1.5A	20W (Tc=25°C)	175	2	50	50	10	150	10	−100	60				180*	17	10*	83		
★	〃 415	〃	〃	〃	120	80	1.5A	20W (Tc=25°C)	175	2	50	50	10	150	10	−100	60				180*	14	10*	83		
★	〃 416	〃	SW	〃	90	50	1.5A	2W	175	5	80	60	1	400				t_{on}<100ns, t_{off}<250ns t_{stg}<190ns						83		
★	〃 417	〃																								
★	〃 418	〃																								
★	〃 419	〃																								
★	〃 420	沖	SW	Si. EP	25	13	80	150	175	0.1	15	130	3	2			t_{on}<15ns, t_{off}<30ns t_{stg}<20ns				h_{FE1}/h_{FE2}>0.13 (3V, 2mA)			87C	2素子複合	
★	〃 421	〃																								

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC422	沖																							
★	〃 423	三洋	RF.Conv.Mix Osc. PA	Si.EP	40		300	500	175	1	35	80	10	20	10	−20					500*	5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	84B	
★	〃 424	〃	〃	〃	40		300	200	175	1	35	80	10	20	10	−20					500*	5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	84B	
★	〃 425	〃	〃	〃	20		300	500	175	1	15	80	10	20	10	−20					500*	5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	84B	
★	〃 426	〃	〃	〃	20		300	200	175	1	15	80	10	20	10	−20					500*	5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	84B	
★	〃 427	〃	RF.Conv.Mix Osc. PA. SW	〃	40	20	100	300	175	1	35	80	6	1	10	−20	50				180*	5	60	49C	
★	〃 428	〃	〃	〃	20	10	100	300	175	1	15	80	6	1	10	−20	50				180*	5	60	49C	
★	〃 429	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si.E	25	12	10	100	150	1	12				6	−1	27	NF < 7 dB (f = 70MHz)			380*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 19ps	23	
★	〃 430	〃	〃	〃	25	12	10	100	150	1	12				6	−1	46	NF < 7 dB (f = 70MHz)			420*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 19ps	23	
	〃 431	新電元	SW	Si.DB	150	100	30A	200W (Tc=25°C)	150	50mA	150	20	5	10A	10	−2A					$f_{\alpha e}$ = 0.4	700		266	
	〃 432	〃	〃	〃	150	100	30A	200W (Tc=25°C)	150	50mA	150	40	5	10A	10	−2A					$f_{\alpha e}$ = 0.4	700		266	
	〃 433	〃	〃	〃	200	140	30A	200W (Tc=25°C)	150	20mA	200	20	5	10A	10	−2A					$f_{\alpha e}$ = 0.4	700		266	
	〃 434	〃	〃	〃	200	140	30A	200W (Tc=25°C)	150	20mA	200	40	5	10A	10	−2A					$f_{\alpha e}$ = 0.4	700		266	○
	〃 435	〃	〃	〃	300	200	30A	200W (Tc=25°C)	150	5mA	300	20	5	10A	10	−2A					$f_{\alpha e}$ = 0.4	700		266	
	〃 436	〃	〃	〃	300	200	30A	200W (Tc=25°C)	150	5mA	300	40	5	10A	10	−2A					$f_{\alpha e}$ = 0.4	700		266	
★	〃 437	三菱	PA	Si.TP	100	70R	2A	13W (Tc=25°C)	175	10	28	20	28	350	28	−300	30				210*	45	8*	83	MT-301
★	〃 438	〃	〃	〃	75	60R	2A	13W (Tc=25°C)	175	100	28	20	28	350	28	−300	30				210*	45	8*	83	MT-302
★	〃 439	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	25	18	100	500	200	0.5	15	50	10	0.1	10	−1	100				420*	3.5	65*	84B	
★	〃 440	〃	〃	〃	25	15	100	500	200	0.5	15	50	10	0.1	10	−1	100				420*	3.5	65*	84B	MTF-156
★	〃 441	〃	〃	〃	25	15	100	500	200	0.01	15	50	10	0.1	10	−1	100				420*	3.5	65*	84B	MTF-157
★	〃 442	〃	〃	〃	50	20	100	500	200	0.01	15	50	10	0.1	10	−1	100				420*	3 5	65*	84B	MTF-158
★	〃 443	〃	PA	〃	50	40R	500	800	200	0.05	28	20	28	100	28	−5	15	PG = 10 dB (f = 70MHz)			200*	10		84B	MTF-206
★	〃 444	〃	〃	〃	60	40	500	800	200	0.01	28	25	28	100	28	−5	20	PG = 12 dB (f = 70MHz)			220*	10		84B	MTF-207
★	〃 445	〃	〃	〃	80	80	500	800	200	0.05	28	30	28	100	28	−5	25	PG = 13 dB (f = 70MHz)			220*	10		84B	MTF-208
★	〃 446	〃	〃	〃	60	40	500	800	200	0.01	28	25	28	100	28	−5	20	PG = 12 dB (f = 70MHz)			220*	10		84B	
★	〃 447	〃	〃	〃	75	60R	2A	5W	175	50	28	20	28	350	28	−100	30				210*	29	8*	112	
★	〃 448	〃	〃	〃	100	70R	2A	5W	175	10	30	20	28	350	28	−100	30				190*	29	8*	112	MTD-306
★	〃 449	〃	〃	〃	75	60R	2A	5W	175	100	30	20	28	350	28	−100	30				190*	29	8*	112	MTD-307
★	〃 450	〃	〃	〃	60	60R	2A	5W	175	100	30	20	28	350	28	−100	30				210*	29	8*	112	MTD-308
★	〃 451	〃	〃	〃	100	80	1.2A	25W (Tc=25°C)	200	100	28	>15	28	350	28	−100	30				180*	20	15*	112	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC452	三菱	PA	Si. TP	100	80	1.2A	25 W (Tc=25°C)	200	500	28	>15	28	350	28	−100	30				180*	20	15*	112	
★	〃 453	〃	〃	〃	90	70	1.2A	25 W (Tc=25°C)	200	500	28	>10	28	350	28	−100	30				170*	20	15*	112	
	〃 454	日立	RF. Conv. Mix	Si. E	30	30	100	200	150	0.5	18	100~500	12	2	12	−2					230*	<3.5		138	
★	〃 455	〃	〃	〃	30		100	200	125	1	18				12	−2	40				230*	1.8	40	37	
★	〃 456	松下	PA. AF	Si. EP	50	50S	600	750	175	1	12	12	6	80	6	−80	20				200*	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	84 B	
★	〃 457	日電	Diff	Si. E	25	12	50	300	175	0.1	10	80	1	1	6	−2		h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0			200*	4.5	40*	87 B	2素子複合
	〃 458	日立	RF. AF	〃	30	30	100	200	150	0.5	18	100~500	12	2	5	−0.1	130	16.5k	0.7	11	230*	<3.5		138	2SA1029とコンプリ
★	〃 459	〃	RF. Conv. Mix	〃	30	30	100	200	125	1	18	160	12	2	12	−2	110	2800	1.6	20	230*	1.8	100	138	
	〃 460	〃	〃	Si.Pa	30	30	100	200	150	0.5	18	35~200	12	2	12	−2					230*	1.8		138	
	〃 461	〃	〃	〃	30	30	100	200	150	0.5	18	35~200	12	2	12	−2					230*	1.8		138	
★	〃 462	〃	RF	〃	40	40	50	200	200	0.5	20				10	−4	90	PG=26dB (f=45MHz)			600*	0.9		9	
★	〃 463	〃	〃	〃	40	40	50	200	200	0.5	20				10	−4	90	PG=15dB (f=200MHz)			600*	0.8		9	フォワードAGC
★	〃 464	〃	RF. Conv Mix. Osc	〃	30	19	50	200	200	0.5	10				6	−1	40	PG=28dB (f=45MHz)			1100*	1	$C_c r_{bb'}$ 10ps	9	
★	〃 465	〃	〃	〃	30	19	50	200	200	0.5	10				6	−1	40				1100*	1	$C_c r_{bb'}$ 10ps	9	
★	〃 466	〃	〃	〃	30	19	50	200	200	0.5	10				6	−1	40	PG=14dB (f=200MHz)			1100*	1	$C_c r_{bb'}$ 10ps	9	
★	〃 467	富士通	SW	Si. EP	20	20R	50	300	175	0.5	10	40	1	10										49 C	
★	〃 468	日立	〃	〃	40	15	200	200	175	1	20	60	1	10	10	−20					450*	4		9	
★	〃 469	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si. E	20	18R	30	100	125	0.1	15	90	3	0.5	6	−1	100				250*	1.6	50*	23	
★	〃 470	ソニー	RF	Si.EP	90	70	100	750	175	1	25	60	5	3	6	−5					150*	2	$C_c r_{bb'}$ 20ps	84 C	
★	〃 471	日立	AF	Si. Me	30	20	100	200	175	0.1	20				6	−0.1	50				160*	7	70	8 A	
★	〃 472	〃	SW	〃	V_{CBX} 30	20	100	200	175	0.1	20	100	6	10				t_{on}<0.1μs, t_{off}<0.5μs t_s<1μs			180*	7	60	8 A	
★	〃 473	〃	〃	Si. TMe	70	50	100	200	175	0.1	20	80	6	10				t_{on}<80 ns, t_{off}<200ns t_s<700ns			180*	4.5	75	8 A	
★	〃 474	〃	〃	Si. Me	V_{CBX} 70	25	100	200	175	0.1	20	60	6	10				t_{on}<0.1μs, t_{off}<0.5μs t_s<1μs			160*	7		8 A	
★	〃 475	日電	RF. AF LN	Si. E	20	15	100	150	150	0.1	15	300	3	0.5	3	−0.5	350	15kΩ	18	3.5	100*			23	
★	〃 476	〃	RF. AF	〃	20	15	100	150	150	0.1	15	350	3	0.5	3	−0.5	400	15kΩ	20	3.8	100*			23	
★	〃 477	松下	RF	Si.EP	50		30	140	175	1	10	170	10	1							230*	Cre 0.5ps		50 C	
★	〃 478	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	50		120	300	175	1	12	20	12	20	12	−1	15				180*	4	$C_c r_{bb'}$ 75ps	49 C	
	〃 479	日立	SW	〃	60	40	600	650	175	1	40	40~160	1	100				t_{on}<80ns, t_{off}<100ns				<20		123	
★	〃 480	〃	〃	〃	60	30	600	800	175	1	30	40~160	1	150				t_{on}<30ns, t_{off}<40ns						123	
★	〃 481	東芝	PA	〃	60	60R	1 A	600	150	10	30	35	2	150	6	−100		Po>1 W (f=50MHz, Vcc=24V, Pi=0.1W)			>100*	<30	<25	84 B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC482	東芝	RF.PA	Si. E	40	32	600	600	175	1	30	30~300	2	150	10	−10					>50*	15	7	84B	
★	〃 483	〃	PA	Si.TMe	100	100R	1 A	15 W (Tc=25°C)	150	1mA	30	120	2	150	2	−30	100				25*	80	5	99	
★	〃 484	〃	〃	〃	150	110	1.5A	800	175	10	30	30~300	2	200	10	−30					20*	50	10	84B	2SA484 とコンプリ
★	〃 485	〃	〃	〃	100	80	1.5A	800	175	10	30	30~300	2	200	10	−30					20*	50	10	84B	2SA485 とコンプリ
★	〃 486	〃	〃	〃	70	50	1.5A	800	175	10	30	30~300	2	200	10	−200					20*	50	10	84B	2SA486 とコンプリ
★	〃 487	〃	〃	〃	110	110R	1.5A	15 W (Tc=25°C)	150	1mA	30	120	2	200	2	−200	100				20*	85	5	99	
★	〃 488	〃	〃	〃	140	110	3 A	16 W (Tc=25°C)	150	3mA	50				5	−0.5A	80				10*	130	5	99	
★	〃 489	〃	〃	〃	100	80	3 A	16 W (Tc=25°C)	150	3mA	50				5	−0.5A	80				10*	130	5	99	
★	〃 490	〃	〃	〃	60	50	3 A	16 W (Tc=25°C)	150	3mA	50				5	−0.5A	80				10*	130	5	99	
★	〃 491	〃	〃	〃	50	35	1.5A	15 W (Tc=25°C)	150	10	30	70	2	0.5A	2	−0.5A	70				40*	40	25	99	
★	〃 492	〃	〃	〃	110	110	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	10mA	50				5	−1A	60				20*	80	15	102	
★	〃 493	〃	〃	〃	80	80	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	10mA	50				5	−1A	60				20*	80	15	102	
★	〃 494	〃	〃	〃	50	50	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	10mA	50				5	−1A	60				20*	80	15	102	
★	〃 495	〃	〃	Si. E	70	50	1 A	1 W	150	1	30	40~240	2	50	10	−10					100*	10		342	2SA505 とコンプリ
★	〃 496	〃	〃	〃	40	30	1 A	1 W	150	1	30	40~240	2	50	10	−10					100*	10		342	2SA496 とコンプリ
	〃 497	〃	〃	〃	100	80	800	600	150	1	30	40~240	2	200	10	−10					50*	15		84B	2SA497 とコンプリ
	〃 498	〃	〃	〃	80	50	800	600	150	1	30	40~240	2	200	10	−10					50*	15		84B	2SA498 とコンプリ
★	〃 499	〃	〃	Si. EP	100	100R	20	300	125	1	18				12	−2	80				150*	2	40	33	
★	〃 500	〃	RF	Si.TMe	120	120R	20	600	150	1	30				30	−3	140				175*	2	40	84A	
★	〃 501	〃	〃	Si.EP	60	30	300	750	175	0.1	30				10	−10	80				200*	4	40	84B	2SA501 とコンプリ
★	〃 502	〃	PA	〃	60	60R	1 A	10 W (Tc=25°C)	150	10	30	30	5	200	5	−200	30	PG = 12dB (f=50MHz, P_{in}=0.1W)						84C	
	〃 503	〃	RF.SW	Si. E	100	80	600	800	175	0.5	80	30~300	2	150	10	−10					80*	13	16	84B	2SA503 とコンプリ
	〃 504	〃	〃	〃	80	60	600	800	175	0.5	60	30~300	2	150	10	−10					80*	13	16	84B	2SA504 とコンプリ
	〃 505	〃	〃	Si. T	300	300	200	600	175	1	100	40~140	5	50	10	−10					60*	<20	<20	84B	
	〃 506	〃	〃	〃	200	200	200	600	175	1	100	40~140	5	50	10	−10					60*	<20	<20	84B	
	〃 507	〃	〃	〃	170	120	100	750	175	0.5	100	70	5	10	20	−10					250*	2.8	50*	84B	
★	〃 508	〃	SW	〃	180	60	4 A	20 W (Tc=25°C)	150	120	50	40	5	4 A	5	−500					25	50		99	
	〃 509	〃	PA.SW	Si. E	35	30	800	600	150	0.1	35	70~240	2	50	10	−10					100*	11		138	2SA509 とコンプリ
	〃 510	〃	〃	Si. T	140	100	1.5A	800	175	1	30	30~150	2	200	10	−30					60*	25		84B	2SA510 とコンプリ
★	〃 511	〃	〃	〃	120		1 A	800	150	3	30				10	−50					50*	30		84B	2SA511 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC512	東芝	PA.SW	Si.T	100	60	1.5A	800	175	1	30	30~150	2	200	10	−30					60*	25		84B	2SA512とコンプリ
★	〃 513	〃	〃	〃	70		1A	800	150	3	30				10	−50	50				50*	30		84B	2SA513とコンプリ
★	〃 514	〃	〃	Si.TMe	300	300	100	4W (Tc=25°C)	150	0.1	300				10	−50	60				20*	7		98A	
★	〃 515	〃	〃	〃	300	300	100	6W (Tc=25°C)	150	100	300				10	−50	60				20*	7		99	○
★	〃 516	〃	RF.PA	Si.DB	100	60	1.5A	800	175	0.5	30	60	2	200	5	−200	60				50*	25	10	84B	
★	〃 516A	〃	〃	〃	140		1.5A	800	175	0.5	30	60	2	200	5	−200	60				50*	25	10	84B	
★	〃 517	〃	PA	Si.EP	60	60R	2A	10W (Tc=25°C)	175	10	30	10~140	5	500	10	−200					300*	25	10	97B	
★	〃 518	〃	〃	Si.TMe	140	140S	5A	50W (Tc=25°C)	150	10mA	50	40	5	5A	5	−5A	40	h_{fe} = 2 (f = 20MHz)				70	10	102	
★	〃 518A	〃	〃	〃	180	180S	5A	50W (Tc=25°C)	150	1mA	50	40	5	5A	5	−5A	40	h_{fe} = 2 (f = 20MHz)				70	10	102	
★	〃 519	〃	〃	〃	110	110	7A	50W (Tc=25°C)	150	10mA	50	30~300	5	1A	10	−1A					10*	90	15	102	
★	〃 519A	〃	〃	〃	130	110	7A	50W (Tc=25°C)	150	100	130	30~300	5	1A	10	−1A					10*	90	15	102	
★	〃 520	〃	〃	〃	80	70	7A	50W (Tc=25°C)	150	10mA	50	30~300	5	1A	10	−1A					10*	90	15	102	
★	〃 520A	〃	〃	〃	100	80	7A	50W (Tc=25°C)	150	100	100	30~300	5	1A	10	−1A					10*	90	15	102	
★	〃 521	〃	〃	〃	50	40	7A	50W (Tc=25°C)	150	10mA	50	30~300	5	1A	10	−1A					10*	90	15	102	
★	〃 521A	〃	〃	〃	70	50	7A	50W (Tc=25°C)	150	100	70	30~300	5	1A	10	−1A					10*	90	15	102	
	〃 522	〃	〃	Si.T	140	100	1.5A	10W (Tc=25°C)	175	1	30	30~150	2	200	10	−30					60*	25	10	97B	
★	〃 523	〃	〃	〃	120	80	1.5A	10W (Tc=25°C)	175	3	30				10	−50	50				50*	25	10	97B	
	〃 524	〃	〃	〃	100	60	1.5A	10W (Tc=25°C)	175	1	30	30~150	2	200	10	−30					60*	25	10	97B	
★	〃 525	〃	〃	〃	70	40	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	3	30				10	−50	50				50*	35	10	97B	
★	〃 526	松下	〃	Si.TMe	165	150	55	2.3W (Tc=25°C)	175	2	12				20	−45	20				250*	2.5	C_c $r_{bb'}$ 25ps	84B	
★	〃 527	〃	RF	Si.P	35		10	130	175	1	10				10	−2.5	50				340*	1	20	50C	
★	〃 528	日立	RF.PA	Si.EP	20	20	150	200	125	0.5	20	100	1	150	6	−1	70				100*	12	35	37	
★	〃 529	〃	RF.AF	Si.P	30	30	100	100	125	0.5	18	160	12	2	12	−2	160	2800	0.7	20	230*	1.8	100	36	
★	〃 530	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	30	30	100	100	125	0.5	18				12	−2	150				230*	1.8	100	36	
★	〃 531	〃	〃	〃	30	30	100	100	125	0.5	18				12	−2	40				230*	1.8	40	36	
★	〃 532	〃	〃	〃	30	30	100	100	125	0.5	18				12	−2	110	PG = 26dB (f = 10.7MHz)			230*	1.8	100	36	
★	〃 533	〃	〃	〃	30	30	100	100	125	0.5	18				12	−2	85	PG = 29dB (f = 10.7MHz)			230*	1.8	40	36	
★	〃 534	〃	〃	〃	30	30	100	100	125	0.5	18				12	−2	85	PG = 17dB (f = 100MHz)			230*	1.8	40	36	
	〃 535	〃	〃	Si.EP	30	20	20	100	150	0.5	10	60~200	6	1	6	−5					940*	0.9	C_c $r_{bb'}$ 5ps	138	
	〃 536	三洋	〃	Si.P	40	30	100	200	125	1	35	320	6	1	6	−1					100*	3	C_c $r_{bb'}$ 250ps	138	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC537	三洋	RF.Conv.Mix Osc.	Si.P	20		100	200	125	1	15	120	6	1	6	−1	80				180*	3	$C_c r_{bb'}$ 250ps	27	
★	〃 538	松下	RF.AF	Si.EP	25	25	50	300	175	1	10	250	5	2	5	−2	250	3500	2.5	35	150*	4.5	70	49C	2SA550とコンプリ ○
★	〃 538A	〃	AF	〃	45	45	80	300	175	1	10	250	5	2	5	−0.5	250	3500	2.5	35	80*	4.5	70	49C	2SA550Aとコンプリ
★	〃 539	〃	RF	〃	25	25	50	300	175	1	10	250	5	2	5	−2	250	3500	2.5	35	80*	4.5	70	49C	
★	〃 540	日電	RF.AF.LN	Si.E	30	25	100	150	150	0.1	25	270	3	0.5	3	−0.5	300	15kΩ	16		100	8	30	23	
★	〃 541	富士通	PA	Si.EP	50	35	1 A	7 W (Tc=25°C)	200	5	30	30	4	100	4	−100	30				400*	7	12*	84B	
★	〃 542	〃	〃	〃	65	40	1.5A	11.6W (Tc=25°C)	200	5	30	25	4	500	4	−150	30				400*	7	10*	111	
★	〃 543	〃	〃	〃	65	40	3 A	23 W (Tc=25°C)	200	12	30	20	4	1 A	4	−200	30				300*	14	7*	111	
★	〃 544	三洋	RF.Conv.Mix Osc.	〃	40		30	120	125	1	30	60	6	1	6	−1					350*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 40ps	27	
★	〃 545	〃	〃	〃	20		30	120	125	1	15	60	6	1	6	−1					350*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 40ps	27	
★	〃 546	〃	〃	〃	30		30	150	125	1	30				10	−2	80				600*	1	$C_c r_{bb'}$ 9ps	27	
★	〃 547	東芝	PA	〃	65	40	1 A	6 W (Tc=25°C)	175	100	30	>10	3	150	28	−100					500*	<10	12	84B	
★	〃 548	〃	RF.PA	〃	36	18	500	6 W (Tc=25°C)	175	100	15				13.5	−100	30				550*	13	10*	84B	
★	〃 549	〃	PA	〃	65	40	1.5A	10 W (Tc=25°C)	175	100	30	>10	3	150	28	−150	30				500*	<10	7	111	
★	〃 550	〃	〃	〃	36	18	1.5A	10 W (Tc=25°C)	175	100	15				13.5	−150	30				400*	18	7*	111	
★	〃 551	〃	〃	〃	65	40	3 A	20 W (Tc=25°C)	175	250	30	>10	3	300	15	−150					400*	<20	6.5*	111	
★	〃 552	〃	〃	〃	36	18	3 A	20 W (Tc=25°C)	175	250	15				13.5	−300	30				350*	40	5*	111	
★	〃 553	〃	〃	〃	55	40	3 A	20 W (Tc=25°C)	175	250	30				28	−200	30				400*	15	6.5*	111	
★	〃 554	〃	〃	〃	36	18	500	6 W (Tc=25°C)	175	100	15				13.5	−100	30				400*	17	10*	84B	
★	〃 555	〃	〃	〃	55	30	400	4.2 W (Tc=25°C)	175	20	28				15	−25					800*	<3.5	25*	84B	
★	〃 556	〃	RF.PA	〃	40	20	400	750	150	25	20				15	−50	45				850*	2.8	100*	84B	
★	〃 557	〃	PA	〃	40	25	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	20	15	50	2	400	10	−200					350*	25	10*	111	
★	〃 558	〃	〃	Si.TMe	250	80	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	1mA	50	40	5	5 A	5	−5A					20	70	10	102	
★	〃 559	〃	〃	Si.EP	60	30	300	600	175	10	30	80	1	100	10	−10		h_{fe}=2.3 (100MHz)				3.2	10	84B	
★	〃 560	東芝	RF	Si.EP	80	60	800	800	175	0.5	30	30~120	2	150	10	−50	70				150*	11	15	84B	2SA560とコンプリ
★	〃 561	富士通	RF.Conv.Mix Osc	Si.P	20		25	200	125	2	12				6	−2	35				200*	2	60*	30	
★	〃 562	松下	RF	〃	40	30	25	130	175	1	10	>26	10	4	10	−4	80				330*	Cre 0.15pF	$C_c r_{bb'}$ 45ps	117C	フォワードAGC
★	〃 563	〃	〃	Si.EP	40	25	25	145	175	1	10	>38	10	7	10	−5	130				550*	Cre 0.23pF	$C_c r_{bb'}$ 80ps	117C	○
	〃 564	富士通	SW	〃	50	50R	500	650	175	1	10	50	1	150				t_r=45ns, t_f=35ns t_s=50ns						84B	
	〃 565	〃	〃	〃	50	50R	200	350	175	1	10	45	1	10				t_r=10ns, t_f=25ns t_s=100ns						49C	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC566	日電	RF. PA	Si. E	50	40	300	800	175	0.2	35	70	10	100	10	−30					700*	4		85B	
★	〃 567	〃	RF	〃	30	15	20	200	150	0.5	15				6	−2	80	NF=1.8dB (f=70MHz)			1300*	0.55	$C_c r_{bb'}$ 3ps	50C	
★	〃 568	〃	〃	〃	30	15	20	200	150	0.1	15				6	−2	80	NF=1.5dB (f=70MHz)			1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 2.1ps	50C	
★	〃 569	東光	SW	Si.EP	40	15	150	150	150	0.5	20	60	1	10				t_r<15ns, t_f<15ns t_s<20ns						22	KT 200
★	〃 570	〃	〃	〃	40	15	200	300	150	0.5	20	60	1	10				t_r<15ns, t_f<15ns t_s<20ns						28	KT 210
★	〃 571	松下	PA	〃	36	18	500	6 W (Tc=25°C)	175	5	20	70	13.5	100	13.5	−100	70				320*	27	5*	84B	
★	〃 572	〃	〃	〃	36	18	1 A	10 W (Tc=25°C)	175	5	20	80	13.5	200	13.5	−200	80				330*	27	5*	111	
★	〃 573	〃	〃	〃	36	18	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	10	20	80	13.5	400	13.5	−400	80				350*	27	4.5*	111	
★	〃 574	〃	RF. PA	〃	80		1 A	7.5W (Tc=25°C)	175	0.5	80	>5	10	500	10	−100	15				280*	15	$C_c r_{bb'}$ 20ps	110	
★	〃 575	〃	〃	〃	80		1 A	5 W (Tc=25°C)	175	0.5	40	20	5	500	10	−100	20				210*	7	$C_c r_{bb'}$ 18ps	84C	
★	〃 576	〃	RF. SW	〃	40	15	500	360	200	0.1	20	40	1	10	6	−2	60	t_d+t_r<12ns, t_s+t_f<15ns t_s<10ns			650*	2.5	20	49C	
★	〃 577	〃	〃	〃	40	15	500	360	200	0.1	20	80	1	10	6	−2	80	t_d+t_r<12ns, t_s+t_f<18ns t_s<13ns			600*	2.5	20	49C	
★	〃 578	日電	SW	Si. E	60	60S	500	600	175	1	30	60	1.5	150				t_d<25ns, t_s<100ns t_r<100ns, t_f<50ns						84B	
★	〃 579	〃	〃	〃	30	30S	200	360	175	0.1	15	80	0.4	50				t_d<35ns, t_s<15ns t_r<40ns, t_f<35ns						49C	
★	〃 580	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	60	30	1 A	800	175	1	40	60	10	150	10	−50	80				250*	10	20*	84B	
★	〃 581	松下	RF. Conv Mix. Osc	Si.EP	30		30	140	175	1	10				10	−1	85				230*	1.5	20	50C	
★	〃 582	〃	PA	Si. Me	300	300	100	6.5W (Tc=70°C)	150	100	300	65	10	50	10	−50	60				35*	8	30	99	
★	〃 583	〃	RF. Conv Mix. Osc	〃	30	15	20	200	200	0.01	15	25~150	1	2	5	−2	80				1300*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 8ps	50C	
	〃 584	〃	RF. PA	〃	80		2 A	17.5W (Tc=25°C)	200	1 mA	80	10	10	500	10	−500	15				200*	30	$C_c r_{bb'}$ 20ps	111	
★	〃 585	〃	PA	Si. EP	65	40	3 A	20 W (Tc=25°C)	175	12	30	80	28	200	28	−200	30				350*	14	6.5*	111	
★	〃 586	〃	〃	Si. EMe	150	150S	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	15mA	150	30	4	5 A	4	−5A	20				55*	130	8	102	
	〃 587	松下, ソニー 東芝	RF	Si. P	45	35	30	300	175	0.01	10				10	−2	300				80*	3	80	49C	
	〃 587A	〃	〃	〃	45	45	30	300	175	0.01	10				10	−2	300	NF<2.5dB (f=1 kHz)			80*	3	80	49C	
★	〃 588	富士通 ソニー	〃	Si. DB	30	20	100	600	175	1	15				10	−10	100				200*	2.5	50	84B	
★	〃 589	ソニー 松下	〃	〃	165	150	80	750	175	2	25	40	5	3	20	−3	40				200*	2	$C_c r_{bb'}$ 35ps	84B	
	〃 590	日電 三菱	〃	〃	120	70	300	800	175	1	60	70	10	150	10	−50	70				150*	12	30*	84B	
	〃 591	富士通, 沖 日電	RF. PA	〃	100	50	1.5 A	20 W (Tc=25°C)	175	1 mA	30	10~40	10	150	10	−150	20				150*	35	25*	83	
★	〃 592	富士通	PA	Si. TP	75	50	2.5 A	13 W (Tc=25°C)	175	1	30	60	4	0.5 A	28	−100	60				180*	20	10*	111	
	〃 593	松下	RF. Conv Mix. Osc	Si. EP	50	30	30	165	175	1	10	40~160	10	1	10	−1	100				230*	1.5	18	50C	
	〃 594	富士通, 沖 日電, 三菱 東芝	RF. PA	Si. E	60	25	200	750	175	0.1	45	40~240	1	10	10	−10					<100*	<5	<120*	84B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC595	沖,東芝 富士通,日電	SW	Si.EP	30	20	200	300	150	1	15	60	1	10	10	−10	60	t_{on}<100ns, t_{off}<100ns t_s<50ns			450*	4	40*	49C	
	〃 596	日電 富士通	RF.PA	〃	60	30	500	800	175	0.5	20	25~100	10	30	10	−30	50				400*	6	40*	85B	
★	〃 597	東芝 松下	PA	〃	65	40	1 A	6 W (T_c=25°C)	175	5	30				28	−100	30				400*	7	12*	84B	
★	〃 598	東芝、沖 日電、松下	〃	〃	65	40	1.5A	10 W (T_c=25°C)	175	5	30				28	−100	30				400*	7	12*	111	
	〃 599	三菱	〃	〃	60	40	1.5A	20 W (T_c=25°C)	200	500	28	30	28	50	28	−50	50	PG = 8 dB (f=220MHz, P_i=1.9W)			500*	25	7*	114	
★	〃 600	東芝、日電 松下	〃	〃	65	40	3 A	20 W (T_c=25°C)	175	12	30				28	−200	30				400*	14	7.5*	111	
	〃 601	松下 富士通	RF.SW	〃	40	15	100	300	175	0.1	20	60	1	10	10	−10	80	t_d+t_r<12ns t_s<13ns, t_s+t_f<18ns			580*	2.4	20	49C	
	〃 602	東芝、沖、 富士通	RF	〃	30	20	30	200	150	1	15				6	−5	60	NF = 5 dB (f = 70MHz)			800*	1.3	70*	50C	
	〃 603	日電	Ch	Si.E	7	4.5R	50	200	150	1	6	100	0.5	0.1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.1~1.0, ΔV_{pi}<100μV $\gamma\Delta V_{pi}$<5μV/°C, ΔI_{pi}<2nA						70*	5.5	$C_c r_{bb'}$ 2ns	47	2素子複合 双方向性
★	〃 604	〃	RF.AF	〃	45	20	100	150	150	1	20				6	−1	80				90*	7	25	23	
★	〃 605	〃	RF.Conv.Mix Osc	Si	30	30	20	150	150	0.2	20	60	10	2	10	−2	70				480*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 2ps	23	フォワード AGC
★	〃 606	〃	〃	〃	30	30	20	150	150	0.2	20	60	10	2	10	−2	70				530*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 1.6ps	23	フォワード AGC
★	〃 607	日立	PA	Si.T	75	60	600	1 W	175	5	40				10	−50	50				70*	25	20*	84A	
★	〃 608	〃	〃	〃	75	60	1.5A	10 W (T_c=25°C)	175	5	40				10	−50	60				70*	25	20*	97B	
★	〃 609	〃	〃	〃	75	60	1.5A	10 W (T_c=25°C)	175	5	40				10	−50	60				80*	25	25*	97B	
	〃 610	松下	〃	Si.TP	100	100R	10A	100 W (T_c=25°C)	175	10mA	40	50	1	1 A				P_o=32W (f=40MHz, V_{CE}=40V, P_i=7.5W)						109	
	〃 611	日電,沖,富士通 東芝、松下	RF.Conv Mix.Osc	Si.EP	20	15	20	200	150	1	10				10	−2	80	NF = 2.5dB (f = 70MHz)			1000*	1	$C_c r_{bb'}$ 3ps	50C	
★	〃 612	東芝、日電 松下	RF	〃	35	15	20	180	175	1	10				10	−2	80	NF = 2.5dB (f = 70MHz)			1300*	1	Z_{rb} 30Ω	50C	
★	〃 613	日電	SW	〃	40	15	200	360	200	0.1	20	80	1	10				t_{on}<25ns, t_{off}<25ns t_s<20ns						49C	
★	〃 614	三洋	Osc.PA	Si.P	80		1.5 A	7.5 W (T_c=25°C)	175	1	40	80	10	250	10	−250					200*	12.5	8	84B	
★	〃 615	〃	〃	〃	30		1.5 A	7.5 W (T_c=25°C)	175	1	10	80	10	250	10	−250					200*	12.5	8	84B	
★	〃 616	〃	〃	〃	80		1.5 A	13 W (T_c=25°C)	175	1	40				10	−250	80				200*	12.5	8	83	
★	〃 617	〃	〃	〃	30		1.5 A	13 W (T_c=25°C)	175	1	10				10	−250	80				200*	12.5	8	83	
	〃 618	富士通	RF	Si.EP	25	13	25	150	150	0.1	12				6	−2	50	NF = 4.5dB (f = 70MHz)			800*	1.3	60*	50C	
	〃 618A	〃	〃	〃	25	13	25	150	150	0.1	12				6	−2	50	NF = 3 dB (f = 70MHz)			800*	1.3	60*	50C	
★	〃 619	三菱	SW.PA	Si.EP	30	15	200	250	125	1	25	110	6	10				t_{on}<40ns, t_{off}<250ns t_{stg}<150ns						138B	
★	〃 620	〃	RF.PA	〃	50	30	200	250	125	1	25	90	6	10	6	−1					250*	7	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	
★	〃 621	〃	RF.Conv.Mix Osc. SW	〃	25	25S	100	150	150	1	25	75	6	10	6	−1	80	2500	0.4	15	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	8A	
★	〃 622	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	25	25S	100	150	150	1	25	75	6	10	6	−1	80	2500	0.4	15	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	11A	
★	〃 623	東光	SW	〃	40	15	150	150	150	0.5	20	60	1	10				t_r<30ns, t_f<30ns t_s<60ns						22	KT-2003

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SC624	東光	SW	Si.EP	40	15	200	300	150	0.5	20	60	1	10				t_r<30ns, t_f<30ns t_s<60ns						28	KT-2103	
★	〃 625	〃																								
★	〃 626	日電	RF.Conv.Mix Osc.PA	Si.E	50	50R	200	750	175	0.1	20				10	−10	130				350*	4	45*	84B		
	〃 627	富士通	RF.AF.SW	Si.T	200	200	100	700	175	5	100	80	10	50	6	−2	50	1000	0.8	10	20*	6	25	84B		
★	〃 628	日電	RF.PA	Si.E	40	20	500	2.5W (T_c=25°C)	175	0.4	20	40	10	100	10	−30	40	P_o=2W (f=200MHz, V_{CC}=15V)			700*	5.5	40*	84B		
★	〃 629	ソニー	RF.Conv Mix.Osc	Si.DB	18		30	150	120	0.2	15	30	3	1	6	−1	36				800*	1.3	C_c $r_{bb'}$ 15ps	38		
★	〃 630	〃																								
★	〃 631	〃	RF.AF.LN	Si.E	25	25	100	250	120	0.2	25	350	3	1	6	−0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	C_c $r_{bb'}$ 350ps	38		○
★	〃 632	〃	RF.LN	〃	40	40	100	250	120	0.2	25	350	3	1	6	−0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	C_c $r_{bb'}$ 350ps	38		○
★	〃 633	〃	RF.Conv.Mix Osc.SW	〃	25	25	100	250	120	0.2	25	400	3	1	6	−2		t_r<60ns, t_f<150ns t_{stg}<500ns			140*	4.5	C_c $r_{bb'}$ 350ps	38		○
★	〃 634	〃	〃	〃	40	40	100	250	120	0.2	25	400	3	1	6	−2		t_r<60ns, t_f<150ns t_{stg}<500ns			140*	4.5	C_c $r_{bb'}$ 350ps	38		○
★	〃 635	日電	PA	Si.E	65	40	1.5A	10W (T_c=25°C)	175	3	18	15~200	10	500	18	−150	50	P_o>4W (f=175MHz, V_{CC}=18V)			450*	10	10*	111		
★	〃 636	〃	〃	〃	65	40	3A	20W (T_c=25°C)	175	10	18	15~200	10	1A	18	−150	50	P_o>7W (f=260MHz)			350*	16	8*	111		
★	〃 637	〃	〃	〃	40	20	1A	10W (T_c=25°C)	175	10	20	>20	13.5	500	13.5	−100	50				500*	16.5	10*	111		
★	〃 638	〃	〃	〃	40	20	2A	20W (T_c=25°C)	175	20	20	>20	13.5	1A	13.5	−200	50				400*	28	8*	111		
	〃 639	〃	SW	〃	40	15	200	360	200	0.1	20	90	1	10	10	−10		t_{on}<12ns, t_{off}<18ns t_s<3ns			750*	1.8		49C		
★	〃 640	〃	RF	〃	30	25	100	150	150	0.1	25	270	3	0.5	3	−0.5	300	15kΩ	16	3	100*	8	30*	23		
★	〃 641	日立	SW.RF	Si.EP	40	15	100	100	150	0.25	20	45~160	0.5	1	10	−10		t_{on}=20ns, t_{off}=35ns t_s=12ns			400*	<6		138		
★	〃 642	東芝	PA	Si.TMe	1100	700R	1A	50W (T_c=25°C)	150	10	500	30~160	15	150	15	−200					2*	55	10	102	水平偏向用	○
★	〃 643	〃	〃	〃	1100	1100S	2.5A	50W (T_c=25°C)	150	10	500	>7	15	2A	15	−200					>2	80	10	102		○
★	〃 644	松下	RF.AF.LN	Si.EP	30	25	50	150	125	1	10	250	5	2	5	−2	200	5000	0.7	10	160*	2.3	C_c $r_{bb'}$ 110ps	138		
★	〃 645	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	30	20	30	140	175	1	10	40~150	10	1	10	−1	100				200*	Cre 0.65	22	243		
★	〃 646	〃	PA	Si.TMe	60	60	4A	25W (T_c=25°C)	150	10mA	60	55	4	2.5A	4	−100	70				50*	110	12	102		
★	〃 647	〃	〃	〃	80	80	5A	50W (T_c=70°C)	150	10mA	80	40	4	4A	10	500					43*	160	7	102		
★	〃 648	日立	RF	Si.E	30	25	30	100	150	0.1	20	280	6	0.1	5	−0.1	320	17kΩ	1.9	12	350*	1.7	80*	182C		
★	〃 649	〃	RF.AF.LN	〃	30	25	30	200	175	0.1	20	120	6	0.1	5	−0.1	150	36kΩ	9.4	3.1	220*	2.7	85	12A		
★	〃 650	〃	〃	〃	30	25	30	200	175	0.1	20	250	6	0.1	5	−0.1	300	86kΩ	2.8	8.5	220*	2.7	75	12A		
★	〃 651	日電	PA	〃	45	22	300	750	150	0.1	20	20~200	10	100	10	−30	80				1100*	2.4	27*	84B		
★	〃 652	〃	〃	〃	40	22	300	750	150	0.2	20	>20	10	100	10	−30	80				1100*	2.4	27*	84B		
★	〃 653	〃	RF	〃	25	13	20	200	150	0.1	12				6	−2	120	NF<4dB (1MHz) NF<22dB (1kHz)			1400*	0.6	60*	50C		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC654	日電	RF	Si.E	40	35	300	800	150	1	35				15	−50	80				650	2.9	21*	85B	
	〃 655	松下	RF.AF.PA	Si.EP	10	10S	10	75	125	1	10	400	5	2	5	−2	250	3500	2.5	35	80*	4.5	70	34	
	〃 656	〃	RF	〃	10		5	50	125	1	10				10	−5	130				550*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 80ps	34	
★	〃 657	ソニー	RF.Conv.Mix Osc	Si.DB	18		30	150	120	0.2	15	50	10	4	6	−1	50				500*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 15ps	38	
★	〃 658	三菱	〃	〃	25	12	20	150	150	1	12	60	6	1	6	−1	60				550*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 30ps	8 A	
★	〃 659	〃	〃	〃	25	12	20	150	150	1	12	60	6	1	6	−1	60				400*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 40ps	8 A	
★	〃 660	〃	RF.Conv Mix	Si.P	25		20	150	150	0.5	20	60	10	3	10	−3	60				600*	1	$C_c r_{bb'}$ 3 ps	11A	フォワードAGC
★	〃 661	〃	〃	〃	25		20	150	150	0.5	20	60	10	3	10	−3	60				600*	1	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	11A	フォワードAGC
★	〃 662	〃	RF.Conv Mix.Osc	Si.EP	25	12	20	150	150	0.5	10				6	−2	40				800*	1	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	9	
★	〃 663	〃	〃	〃	25	12	20	150	150			10〜300	10	10							900*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	11A	
★	〃 664	日立	PA.SW	Si.T	100	50	5 A	50 W (T_c=25°C)	150	1mA	30	80	5	1 A										102	
★	〃 665	〃	〃	〃	130	80	7 A	50 W (T_c=25°C)	150	200	30	30〜130	5	5 A										102	
★	〃 666																								
★	〃 667	東芝																							
	〃 668	三洋	RF.Conv. Mix.	Si.TP	25	20	30	150	125	1	10	25〜560	6	1	6	−1					600*	C_{rc} 0.75	$C_c r_{bb'}$ <30ps	92	
★	〃 669	ソニー	PA	Si.E	30	25	2 A	1 W	175	5	25	70	2	100	10	−50	70				65*	18		181	
★	〃 669A	〃	〃	Si.EMe	100	60	3 A	10 W (T_c=25°C)	175	3	25	170〜400	2	100	10	−50	70				65*	35		181	
★	〃 670	〃																							
★	〃 671	〃																							
★	〃 672	〃																							
★	〃 673	〃																							
★	〃 674	三洋	RF. Conv. Mix.	Si.TP	25	20	30	150	125	1	10	40〜320	6	1	6	−1					600*	C_{rc} 0.75	$C_c r_{bb'}$ 17ps	92	
	〃 675	芝電	SW	Si.Me	250	120	7 A	50 W (T_c=25°C)	180	10	30	30	10	0.5A				t_r<0.5μs, t_f<0.5μs t_s<2.5μs						102	
	〃 676	〃	〃	〃	200	100	7 A	50 W (T_c=25°C)	180	10	30	30	10	0.5A				t_r<0.5μs, t_f<0.5μs t_s<2.5μs						102	
	〃 677	〃	〃	〃	150	80	7 A	50 W (T_c=25°C)	180	30	30	40	10	0.5A				t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_s<3.5μs						102	
	〃 678	〃	〃	〃	100	60	7 A	50 W (T_c=25°C)	180	100	30	40	10	0.5A				t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_s<3.5μs						102	
★	〃 679	日立	PA	Si.T	300		2 A	30 W (T_c=25°C)	175	1	30	60	10	20	10	−200	190				20*	75	20	153	
★	〃 680	〃	〃	〃	200	120	2 A	12.5 W (T_c=25°C)	150	1	30	180	10	200	10	−200	190				20*	75	20	153	○
	〃 681	〃	SW	〃	200	70	6 A	50 W (T_c=25°C)	150	I_{CBX} 15mA	200							t_f<0.5μs						102	水平偏向用 ○
★	〃 682	〃	RF	Si.P	20	20	20	180	175	0.1	10	60	10	2	10	−2	75	PG = 28dB (f = 45MHz)			550*	C_{re} 0.37		9	フォワードAGC

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC683	日立	RF	Si.P	20	20	20	180	175	0.1	10	60	10	2	10	−2	75	PG = 21dB (f = 200MHz)			550*	Cre 0.37		9	フォワードAGC
★	〃 684	〃	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	30	19	50	200	125	0.5	10	>40	10	10	10	−10	50	P_{osc} = 8 mW (f = 930MHz)			1100*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	37	
★	〃 685	〃	PA	Si.T	300	300	100	4 W (T_c=25°C)	150	5	150	60~120	10	50	10	−50					25*	5		153	
★	〃 686	日電	RF	Si.E	150	150	50	800	175	0.01	100	90	10	25	10	−25	100				180*	2.6	10*	84B	
★	〃 687	松下	SW	Si.EP	150	150S	5 A	50 W (T_c=25°C)	150	15mA	150	30	4	5 A				t_r < 2 μs, t_f < 1 μs t_s < 2 μs						102	
★	〃 688	三菱	PA	〃	60	40	1.5A	20 W (T_c=25°C)	200	500	25				10	−100	30	PG = 8.5dB (f=150MHz, P_i=1.9W)				20		114	
	〃 689	日立	SW	〃	40	15	100	300	175	0.25	20	85	1	10	10	−10		t_{on}=6.5ns, t_{off}= 8 ns t_{stg}= 3 ns			>600*	1.8		49C	
	〃 690	三菱	PA	〃	60	40	3 A	30 W (T_c=25°C)	175	500	30	50	10	100				P_o=25W (f=150MHz, V_{CC}=25V, P_i=5W)						113	
★	〃 691	〃	〃	〃	60	40	00	8.6 W (T_c=25°C)	175	200	30	50	10	100				P_o=3.5W (f=150MHz, V_{CC}=24V, P_i=0.3W)						113	
★	〃 692	〃	〃	〃	60	40	1 A	15 W (T_c=25°C)	175	200	30	50	10	100				P_o= 9 W (f=150MHz, V_{CC}=28V, P_i=3W)						113	
	〃 693	三洋	RF. LN	Si.P	40	20	50	100	125	1	35	160~960	6	1	6	−1					100*	4		138	
★	〃 694	〃	〃	〃	40	15	50	100	125	1	35	160~960	6	1	6	−1					100*	4		138	
★	〃 695	日電	AF.RF	Si.E	20	15	30	100	150	0.1	15	150	3	0.1	6	−1	200	6000	0.9	20	150*	2	50*	23	
★	〃 696	松下	PA	Si.EP	100	60	3 A	750	175	3	30	55	V_{CB} = 2 V	100	2	−100	80				100*	20	$C_c r_{bb'}$ 40ps	84B	2SA546とコンプリ
★	〃 696A	〃	〃	〃	130	80	3 A	750	175	3	30	55	V_{CB} = 2 V	100	2	−100	80				100*	20	$C_c r_{bb'}$ 40ps	84B	2SA546Aとコンプリ
★	〃 697	〃	〃	〃	100	60	3 A	10 W (T_c=25°C)	175	3	30	55	V_{CB} = 2 V	100	2	−100	80				100*	22	$C_c r_{bb'}$ 40ps	97B	2SA547とコンプリ
★	〃 697A	〃	〃	〃	130	80	3 A	10 W (T_c=25°C)	175	3	30	55	V_{CB} = 2 V	100	2	−100	80				100*	22	$C_c r_{bb'}$ 40ps	97B	2SA547Aとコンプリ
★	〃 698	日電	RF.PA	Si.E	100	60	3 A	10 W (T_c=25°C)	175	1	60	80	2	0.5A	10	−50	85				90*	35	15*	97B	
★	〃 699	三菱	PA	Si.TP	50	50R	1 A	10 W (T_c=25°C)	200	50	12				12	−100	30	PG = 9 dB (f = 27MHz, P_i=0.5W)				20		97B	
★	〃 700	〃	〃	Si.EP	60	40	500	5 W (T_c=25°C)	200	100	20				20	−50	30	PG = 11dB (f = 150MHz, P_i=0.2W)				6		84C	
★	〃 701	〃	〃	〃	40	25	750	5 W (T_c=25°C)	200	100	15				15	−50	30	PG = 10dB (f = 150MHz, P_i=0.2W)				7		84C	
★	〃 702	〃	〃	〃	40	20	750	8.6 W (T_c=25°C)	175	100	15	50	10	100				P_o= 3 W (f=150MHz, V_{CC}=15V, P_i=0.25W)						113	
★	〃 703	〃	〃	〃	40	20	2 A	21 W (T_c=25°C)	175	1mA	15	50	10	100				P_o=12W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=3.5W)						113	
★	〃 704	〃	〃	〃	40	20	4 A	34 W (T_c=25°C)	175	2mA	15	50	10	100				P_o=17W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=5.5W)						113	
★	〃 705	三洋	RF. Conv. Mix. Osc.	〃	15	15	30	120	125	1	10	70	6	1	6	−1					700*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 14ps	27	
★	〃 706	〃	RF	〃	15	10	30	120	125	1	10	80	6	1	6	−1					800*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 17ps	27	
★	〃 707	日立	RF	Si.P	20	20	20	150	175	0.1	10	50	10	2	10	−2	75	PG = 12dB (f = 800MHz)			650*	0.4		9	
	〃 708	〃	SW	Si.T	60	50	1 A	750	150	10	30	30~160	4	50	4	−30					15*	25		84B	2SA537とコンプリ
	〃 708A	〃	〃	〃	100	80	1 A	750	150	10	30	30~160	4	50	4	−30					15*	25		84B	2SA537Aとコンプリ
★	〃 709	三菱	RF. Conv Mix. Osc	Si.EP	25	12	100	200	125	1	25	75	6	10	6	−1	60				180*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 180ps	138B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC710	三菱	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	30	25	30	200	125	1	25	90	6	1	6	−1					200*	2	$C_c r_{bb'}$ 20ps	138B	
★	〃 711	〃	RF.AF	〃	30	25	100	200	125	0.1	25	250	6	1	6	−1		8500	0.6	40	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 200ps	138B	○
★	〃 712	〃	AF	〃	30	25	100	200	125	1	25	90	6	10	6	−1		2500	0.4	15	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138B	
★	〃 712A	〃	〃	〃	30	25	100	200	125	1	25	75	6	10	6	−1	80	2500	0.4	15	180*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138B	
★	〃 713	〃	SW	〃	30	25	100	200	125	0.1	25	90	6	10				t_{on}<60ns, t_{off}<150ns t_{stg}<120ns			150*	2.5		138B	
★	〃 714	〃	〃	〃	70	40	200	250	125	0.1	25	60	6	10	6	−10		t_{on}<40ns, t_{off}<250ns t_{stg}<150ns			200*	7		138B	
★	〃 715	三洋	RF.V	〃	40	15	100	120	125	1	35	180	6	1	6	−1		3500	0.8		140*	4	$C_c r_{bb'}$ 250ps	27	
★	〃 716	〃	〃	〃	20	15	100	100	125	1	15	180	6	1	6	−1		3500	0.8	13	140*	4	$C_c r_{bb'}$ 250ps	27	
★	〃 717	日立	RF.Conv.Mix Osc	〃	30	19	50	200	125	0.5	10	>40	10	10	6	−1	40	PG=18dB (f=200MHz)			1100*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	37	
	〃 718	富士通	SW	〃	20	15	200	300	175	0.4	15	60	1	10	10	−10		t_r=4ns, t_f=9ns t_s=6ns			800*	2		49C	
	〃 719	〃	〃	〃	20	15	200	200	175	0.4	15	60	1	10	10	−10		t_r=4ns, t_f=9ns t_s=6ns			800*	2		46C	
★	〃 720	〃	RF	Si.P	25		20	200	175	0.05	6				6	−2	100	PG=30dB (=45MHz)			500*	1.2	80*	50C	フォワードAGC
★	〃 721	〃	〃	〃	25		20	200	120	0.05	6				6	−2	100	PG=30dB (f=45MHz)			500*	1.4	80*	30	フォワードAGC
★	〃 722	〃	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	20		25	200	125	0.5	12				6	−2	80				700*	1.5	80*	138	
★	〃 723	〃	〃	Si.P	20		25	200	125	1	12				6	−2	60				500*	1.5	80*	138	
	〃 724	〃	RF.SW	Si.EP	30	20	200	200	125	0.05	10	60	1	10	6	−2	70	t_r<20ns, t_f<50ns t_s<250ns			250*	4	80*	138	
	〃 725	〃	〃	〃	60	50R	200	200	125	0.05	10	60	1	10	6	−2	70	t_r<20ns, t_f<50ns t_s<250ns			250*	4	80*	138	
	〃 726	〃	SW	〃	20	15	200	200	125	1	15	60	1	10		−2		t_r=4ns, t_f=9ns t_s=6ns						30	
	〃 727	〃	RF.AF.SW	Si.T	100	100	100	350	175	1	30	90	4	10	6	−2	60	1200	1	12	20*	9	40	49C	
	〃 728	〃	〃	〃	200	200	100	350	175	1	30	90	4	10	6	−2	60	1200	1	12	20*	10	40*	49C	
★	〃 729	日電	RF	Si.E	50	23	200	600	175	0.5	30				10	−10	60				250*	4	40	84B	
	〃 730	三菱	PA	Si.EP	40	40R	400	1.03W	175	10	15	50	10	100				P_o=1.5W (f=150MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.1W)						84B	
★	〃 731	松下	〃	〃	40	20	500	2.5W (T_c=25°C)	175	1	20	70	13.5	100				P_o=1.2W (f=500MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=0.3W)						84B	
★	〃 732	東芝	LN	Si.E	60	50	150	400	125	0.1	60	200~700	6	2	6	−1					150*	2		138	
	〃 733	〃	RF	〃	35	30	100	300	125	0.1	18	70~700	6	2	6	−1					>80*	7	$C_c r_{bb'}$ 150ps	33	
★	〃 734	〃	〃	〃	70	50	150	300	125	0.1	18	70~400	1	20	6	−10					150*	5	15	33	2SA561とコンプリ
★	〃 735	〃	〃	〃	35	30	400	300	125	0.1	18	70~400	1	100	5	−50					300*	7	$C_c r_{bb'}$ 150ps	33	
★	〃 736	日電	SW	〃	135		5A	50W (T_c=25°C)	175	500	60	60	10	1A				t_{on}<2μs, t_{off}<4μs t_{stg}=3μs						102	
★	〃 737	三菱	PA	Si.EP	60	40	1.5A	17W (T_c=25°C)	175	500	30	50	10	100				P_o=14W (f=150MHz, V_{CC}=25V, P_{in}=1.9W)						113	
	〃 738	〃	RF Conv. Osc	〃	25	12	20	150	125	1	12	55~180	6	1	6	−1		MAG=25.5dB (f=100MHz)			440*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 30ps	138B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC739	三菱	RF. Conv Mix. Osc	Si. EP	25	12	20	150	125	1	12				6	−1	60				350*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 30ps	138B	
★	〃 740	〃	〃	〃	25	12	20	150	150	0.5	10	40	10	10	10	−10	40				900*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	11A	
	〃 741	〃	PA	〃	40	40R	300	2.5W (T_c=25°C)	175	1	15	50	10	100				P_o=0.3W (f=150MHz, V_{CC}=13.5V, P_{in}=10mW)						84B	
★	〃 742	富士通	〃	〃	65	40	1.5A	12.5W (T_c=25°C)	175	5	30				10	−150	30				400*	8	10*	111	
★	〃 743	〃	〃	〃	65	40	3 A	25 W (T_c=25°C)	175	10	30				10	−300	30				350*	16	7*	111	
★	〃 744	〃																							
★	〃 745	〃	PA	Si. EP	50	40	1.5A	12.5W (T_c=25°C)	175	10	10				10	−150	45				450*	8	8*	111	
★	〃 746	〃	〃	〃	45	36	3 A	25 W (T_c=25°C)	175	20	10				10	−300	35				350*	20	6*	111	
★	〃 747	〃																							
★	〃 748	〃	PA	Si. EP	36	18	1 A	12.5W (T_c=25°C)	175	10	10				10	−150	25				400*	16	7*	111	
★	〃 749	〃	〃	〃	36	18	2 A	25 W (T_c=25°C)	175	25	10				10	−300	25				350*	32	5*	111	
★	〃 750	〃																							
★	〃 751	東芝	RF	Si. EP	20	12	20	100	150	1	10				10	−8	50				650*	1.9	30	46C	
	〃 752	〃	SW	Si. E	40	15	200	400	125	0.1	40	40~240	1	10	10	−10					400*	4	30	138	
★	〃 753	日電	RF. Conv. Mix Osc	〃	25		20	100	150	1	12				6	−2	70				1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 12ps	23	
★	〃 754	〃	RF. AF	〃	20	15	150	150	150	1	20	100	1	20	6	−1	80				90*	6.5	25	23	
★	〃 755	〃	RF	〃	15		100	150	150	0.1	15	270	3	0.5	3	−0.5	300	15kΩ	16	3	100*	8	30*	23	
★	〃 756	ソニー	PA	〃	100	60	4 A	10 W (T_c=25°C)	175	3	50	80	2	100	10	−50	60				65*	35	$C_c r_{bb'}$ 50ps	181	○
★	〃 757	日電	RF. Conv. Mix Osc	〃	30		20	100	150	1	12				6	−2	70				1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 10ps	23	
	〃 758	芝電	PA	Si. TMe	280	120	8 A	60 W (T_c=25°C)	150	10	30				5	−0.5A	35				18*	275	10	102	
	〃 759	〃	〃	〃	180	100	8 A	60 W (T_c=25°C)	150	10	30				5	−0.5A	35				18*	275	10	102	
	〃 760	〃	〃	〃	100	60	8 A	60 W (T_c=25°C)	150	100	30				5	−0.5A	35				18*	275	10	102	
★	〃 761	松下	RF. Conv Mix. Osc	Si. P	30	20	20	150	175	100	30	>25	10	2	10	−2	40	PG = 8dB (f = 900MHz)			675*	Cre 0.28	60	50C	フォワードAGC
★	〃 762	〃	〃	〃	30	20	20	150	175	100	30	>25	10	2	10	−2	40				600*	Cre 0.28	60	50C	フォワードAGC
	〃 763	三菱	〃	Si. EP	25	12	20	100	125	0.5	12	70	6	1	6	−1					470*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 15ps	138B	
	〃 764	日電	SW	Si. E	40	40S	200	360	200	0.1	20	85	1	10	10	−10	80	t_{on}<12ns, t_{off}<18ns t_{stg}<13ns			750*	2	$C_c r_{bb'}$ 25ps	49C	
★	〃 765	三菱	PA	Si. TMe	60	40	2 A	30 W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	60	4	1 A				P_o=20W (f=27MHz, V_{cc}=25V, P_i=3W)						102	
★	〃 766	〃	〃	〃	120	80	2 A	30 W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	60	4	1 A				P_o=19W (f=27MHz, V_{cc}=35V, P_i=2W)						102	
★	〃 767	〃	〃	〃	180	120	2 A	30 W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	60	4	1 A				P_o=19W (f=27MHz, V_{cc}=35V, P_i=2W)						102	
★	〃 768	〃	PA. SW	〃	60	40	10A	50W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	25	4	2 A				t_r<3μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs						102	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC769	三菱	PA. SW	Si. TMe	120	80	10 A	50 W (Tc=25°C)	150	1mA	30	25	4	2 A			t_r < 3 μs, t_f < 1 μs t_{stg} < 2 μs							102		
★	〃 770	〃	〃	〃	200	100	10 A	50 W (Tc=25°C)	150	1mA	30	25	4	2 A			t_r < 3 μs, t_f < 1 μs t_{stg} < 2 μs							102		
★	〃 771	〃	〃	〃	250	120	10 A	50W (Tc=25°C)	150	1mA	30	25	4	2 A							t_r < 3 μs, t_f < 1 μs t_{stg} < 2 μs			102		
★	〃 772	三洋	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. EP	15	10	30	120	125	1	10	60	6	1	6	−1					300*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 30ps	27		
★	〃 773	三菱	Osc	〃	50	30	200	250	125	1	25				6	−10	60	P_{osc} = 40mW (f = 27MHz)						138B		
★	〃 774	〃	PA	〃	50	30	500	680	175	10	30	70	10	100				P_{osc} = 70mW (f = 27MHz, V_{CC} = 12V, I_C = 25mA)						84 B		
★	〃 775	〃	〃	〃	75	35	1 A	800	200	10	30	70	10	100				P_o = 0.7W (f = 27MHz, V_{cc} = 12V, P_i = 30mW)						84 B		
★	〃 776	〃	〃	〃	75	35	1 A	1 W	200	10	30	70	10	100				P_o = 1.5W (f = 27MHz, V_{cc} = 12V, P_i = 75mW)						84 B		
★	〃 777	〃	〃	〃	75	35	1 A	2 W	200	10	30	50	10	100				P_o = 3.5W (f = 27MHz, V_{cc} = 12V, P_i = 0.4W)						97 B		
★	〃 778	〃	〃	〃	80	40	2 A	2.5W	200	10	30	50	10	100				P_o = 4 W (f = 27MHz, V_{cc} = 12V, P_i = 0.4W)						97 B		
	〃 779	東芝	SW	Si. TMe	300	250	2 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	200	30~200	10	100	10	−100		t_{on} < 2 μs, t_f < 3 μs t_{stg} < 4 μs			20*	40		99		
★	〃 780	〃	RF	Si. EP	70	70	20	150	125	5	70				10	−2	60				100*	3	50	33		○
★	〃 781	日電	RF. PA	Si. E	75	40	1 A	5 W (Tc=25°C)	175	1	40	80	10	150	10	−150	80				350*	11	13*	84B		
★	〃 782	東芝	PA	Si. TMe	300	300	1.5A	20 W (Tc=25°C)	150	100	200	30~240	10	100	10	−100					10*	50	25	99		○
★	〃 783	〃	〃	〃	200	200	1.5A	20 W (Tc=25°C)	150	100	200	30~240	10	100	10	−100					10*	50	25	99		
★	〃 784	〃	RF	Si. EP	40	30	20	100	125	0.5	18	25~140	6	1	6	−1					500*	C_{re} 0.65	$C_c r_{bb'}$ 10ps	33		
★	〃 785	〃	Conv. Mix Osc	〃	40	30	20	100	125	0.5	18	25~140	6	1	6	−1					500*	C_{re} 0.65	$C_c r_{bb'}$ 10ps	33		
★	〃 786	〃	RF	〃	20	20	20	200	150	0.05	10	20~200	5	4	10	−4		NF = 3.5dB (f = 100MHz)			>250*	C_{re} 0.25~0.55	<25	50C		
★	〃 787	〃	RF. LN	Si. P	25	20	20	150	150	0.025	10	>25	10	2	10	−2		NF = 5dB (f = 800MHz)			1000*	C_{re} 0.3		50C		
★	〃 788	〃	RF. SW	Si. T	250	150	50	800	150	0.1	30	25~240	5	10	30	−10					120*	4	25	84B		
★	〃 789	〃	RF. PA	Si. T	70	60	4 A	30W (Tc=25°C)	150	30	50	40~240	5	500	5	−500					>3*	150		268		
	〃 790	〃	PA	〃	50	40	3 A	25W (Tc=25°C)	150	10	30	40~240	2	500	2	−500					10*	85		268	2SA490 とコンプリ	
★	〃 791	〃	〃	Si. TMe	90	60	1.5A	15 W (Tc=25°C)	150	10	30	40~250	2	200	5	−500					20	40		99		
★	〃 792	〃	〃	〃	300	300	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	50	300	30~250	10	300	10	−100					10*	80		102		
★	〃 793	〃	〃	Si. TMe	100	80	7 A	60 W (Tc=25°C)	150	1mA	30	30~200	5	1 A	5	−500					9*	220		102		
★	〃 794	〃	〃	〃	70	50	7 A	60 W (Tc=25°C)	150	1mA	30	50	5	1 A	5	−500	50				9*	230	15	102		
★	〃 795	ソニー	〃	Si. DB	250	250	100	9 W (Tc=25°C)	150	10	100	70	10	10	10	−10	70				180*	7	$C_c r_{bb'}$ 50ps	100		
★	〃 796	富士通	RF. Osc	Si. EP	40	30	500	1 W (Tc=25°C)	175	5	12	50	4	150	20	−15					230*	5	20*	84B		
★	〃 797	〃	PA	〃	60	35	500	1 W (Tc=25°C)	175	5	12	30	4	150	20	−15	P_o = 1.3W (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=75mW)				150*	5	12*	84 B		
★	〃 798	〃	〃	Si. TP	60	35	1.5A	5 W (Tc=25°C)	175	5	12	70	4	400			P_o = 3.5W (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.5W)							84 B		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC799	日電	RF. PA	Si. E	80	40	1.5A	10W (Tc=25°C)	175	1	40	90	10	150	10	−150	P_o = 3.5W (f = 27MHz, V_{cc} = 12V, P_i = 0.4W)				250*	15		97B		
★	〃 800	〃	RF	〃	30	25	10	100	150	0.1	25	100	6	2	6	−2	85				1000*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	23		
★	〃 801	〃	RF. PA	Si.TMe	75	50	500	13 W (Tc=25°C)	175	1	50	50	10	150	10	−50	45				100*	32	12*	83		
★	〃 802	富士通	PA. SW	Si. EP	60	35	500	1 W (Tc=25°C)	175	5	12	30	4	150	20	−15	P_o = 1.3W (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=75mW)				180*	5	12*	84B		
★	〃 803	〃	〃	Si. TP	60	35	1.5A	5 W (Tc=25°C)	175	1	12	70	4	400			P_o = 3.5W (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.5W)				90*	9	7*	84B		
★	〃 804	ソニー	RF. Conv. Mix. Osc	Si. DB	15	13	20	150	100	0.5	15	50	3	1	6	−4		h_{fe} = 12 (f = 100MHz)				0.32	40*	139		
★	〃 805	〃	RF. AF. SW	Si. DB	100	100	200	475	120	1	25	100	5	3	10	−2					160*	3	$C_c r_{bb'}$ 80ps	181		○
★	〃 806	〃	PA	Si. TMe	650		10 A	125W (Tc=25°C)	150	5mA	500	30	3	2 A	10	−0.5A	50				5*	280	5	102		○
★	〃 807	〃	〃	〃	500	220	10 A	125W (Tc=25°C)	150	5mA	500	50	3	100	10	−0.5A	50				5*	300	5	102		○
★	〃 808	〃	〃	〃	300	100	5 A	80W (Tc=25°C)	150	30	50	100	3	2 A	10	−500					12*	310	$C_c r_{bb'}$ 700 ps	102		
	〃 809	富士通	RF	Si. EP	25	13	20	200	150	0.1	12				6	−2	90				1200*	1.4	40*	50C		
	〃 810	〃	RF. PA	〃	40	35	300	500	150	1	35				15	−50	70				750*	3.8	25*	85B		
★	〃 811	〃	RF	〃		25	30	180	175	0.5	15	60	10	2	10	−2					800*	0.9	50	50C		
	〃 812	〃	SW	〃	20	20S	100	250	150	0.5	10	50	1	10				t_r < 10ns, t_f < 15ns t_{stg} < 12ns				2.5		49C		
★	〃 813	〃																								
★	〃 814	日電	RF. PA	Si. E	30	18	500	400	125	0.2	18	150	5	50	10	−10	140				180*	13	25	44		
★	〃 815	〃	RF. Osc PA	〃	60	45	200	250	125	0.1	45	80	1	50	10	−10	80				200*	5.5	25	138	2SA539 とコンプリ	
★	〃 816	三菱	RF	Si.EP	60	30	1 A	1 W	200	10	28	100	6	0.1	10	−30					140*	12	$C_c r_{bb'}$ 60ps	84B		
★	〃 817	〃	〃	〃	30	15	20	120	150	0.1	12	80	10	1				G_{pe} = 13dB (f = 500MHz, V_{cc} = 6V, I_C = 4mA)						50C		
★	〃 818	〃		Si. TP	160	120	100	800	200			20〜180	10	10							100*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 14ps	84A		
★	〃 819	日立	PA	Si. EP	65	40	1 A	6 W (Tc=25°C)	175	100	65				28	−100	30				500*	7.5	12	84C		
★	〃 820	〃	〃	〃	65	40	1.5A	10 W (Tc=25°C)	175	100	65				28	−100	30				500*	7.5	10	111	スタッドはインチネジ	
★	〃 821	松下	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	40	20	300	2.5W (Tc=25°C)	175	1	20				13.5	−100	70				450*	6.5	15*	84B		
★	〃 822	〃	〃	〃	40	20	500	2.5W (Tc=25°C)	175	1	20				13.5	−100	70				550*	6.5	15*	84B		
★	〃 823	日電	RF	Si. E	30	19	60	600	150	0.1	10	>30	10	15	10	−15	130	NF < 3.5dB (f = 150MHz)			1500*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 3 ps	85B		
★	〃 824	〃	〃	〃	50	25	120	650	150	0.1	10	>20	10	30	10	−50	130	NF < 4.3dB (f = 150MHz)			1300*	2.2	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	85B		
	〃 825	富士通	SW	Si. T	300	300	2 A	30 W (Tc=25°C)	175	20	150	75	10	0.5A				t_r < 2 μs, t_f < 3 μs t_{stg} < 6 μs						99		
	〃 826	〃	RF	Si. TMe	100	60	300	700	175	1	30	100	4	50	30	−10					20*	10	30	84B		
	〃 827	〃	RF. SW	〃	100	60	500	700	175	1	30	100	4	50	30	−10		t_{on} < 0.2μs, t_f < 0.2μs t_{stg} < 2 μs			20*	10	30	84B		
	〃 828	松下	RF. AF	Si. EP	30	25	50	400	150	1	10	130〜520	5	2	10	−2	220	3600	0.4	20	220*	2.2	70	138	2SA564 とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SC828A	松下	RF. AF	Si. EP	45	45	50	400	150	1	10	130~520	5	2	10	−2	220	3600	0.4	20	220*	2.2	70	138	2SC564A とコンプリ
	〃 829	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	30	20	30	400	150	1	10	70~250	10	1	10	−1	130				230*	1.3	35	138	
★	〃 830	日立	PA	Si. T	100	55	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	20	30~200	4	1 A	4	−1 A					6*	120		153	2SB551 とコンプリ
★	〃 831	日電	PA	Si. E	50	25	2 A	23 W (Tc=25°C)	175	5	20	15~200	10	1 A	10	−30	80	P_o=12 W (V_{CC}18V, P_i=2W, f=260MHz)			500*	18		111	
★	〃 832																								
	〃 833	日立,東芝 三洋,富士通	SW	Si. TMe	450	300	2 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	200	80	10	100	10	−100	100	t_{on}<2μs, t_{off}<3μs t_{stg}<4μs				50		134	
★	〃 834																								
★	〃 835																								
★	〃 836	日電	RF	Si	30	30	20	200	125	0.2	20	70	10	4	10	−4	60				600*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 3 ps	138	フォワード AGC
★	〃 837	〃	〃	Si. E	30	30	20	250	125	0.2	20	40	10	10	10	−10	30	PG=20dB (f=45MHz)			550*	1.6		138	
★	〃 838	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	50	25	30	250	125	0.1	15	80	3	0.5	6	−1	90				250*	1.8	$C_c r_{bb'}$ 20ps	138	
★	〃 839	〃	〃	〃	50	25	50	250	125	0.1	15	100	3	0.5	6	−1	90	NF=2.5dB (f= 1 MHz)			250*	2	$C_c r_{bb'}$ 25ps	138	
★	〃 840	松下	PA	Si. TMe	100	60	2 A	20 W (Tc=25°C)	150	5mA	100	60	3	1 A	3	−100	60				50*	90	25	99	
★	〃 840A	〃	RF. Conv Mix. Osc	Si. EP	150	100	2 A	20 W (Tc=25°C)	150	5mA	100	60	3	1 A	3	−100	60				50*	90	25	99	
★	〃 841	富士通	PA	〃	36	20	500	6 W (Tc=25°C)	175	5	12	50	4	500	12	−150					450*	12	12*	84 B	
★	〃 842	〃	〃	〃	36	20	1 A	10 W (Tc=25°C)	175	5	12	40	4	1 A	12	−150					450*	13	10*	111	
★	〃 843	〃	〃	〃	36	20	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	12	12	50	4	2 A	12	−150					350*	25	7*	111	
★	〃 844	〃	〃	〃	40	20	400	3.5 W (Tc=25°C)	175	1	12	25	5	100	15	−30	40	P_o=1.1W (f=175MHz, V_{CE}=12V)			800*	3	20*	84 B	
★	〃 845	〃	〃	〃	55	30	400	3.5 W (Tc=25°C)	175	1	12	25	5	100	15	−30	40	P_o=1.4W (f=100MHz, V_{CE}=28V)			800*	3	20*	84 B	
★	〃 846	日電																							
	〃 847	富士通	RF	Si. EP	30	20	200	350	175	0.5	12	160	4	10	6	−1					70*	10	40	49 C	
	〃 848	〃	RF. LN	〃	30	20	200	350	175	0.1	12	160	4	10	6	−1		3500	0.1	5	60*	10	40	49 C	
	〃 849	〃	SW. AF	〃	30	20	300	350	175	0.5	12	160	4	10	6	−1		3500	0.1	5	t_r<0.08μs, t_f<0.15μs t_{stg}<0.8μs			49 C	
	〃 850	〃	SW. PA	〃	50	30	500	350	175	0.5	12	160	4	10	6	−1		t_r<0.08μs, t_f<0.15μs t_{stg}<0.8μs			70*			49 C	
★	〃 851	日電	PA	Si. E	50	25	8 A	75 W (Tc=25°C)	200	500	30	50	5	5 A				P_o=40W (f=50MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=6 W)						102A	
★	〃 852	〃	RF	〃	45	25	80	500	150	0.5	15	100	6	20	6	−20					1100*	2	$C_c r_{bb'}$ 3.7ps	85 B	
★	〃 853	日電	RF. PA	〃	70	60	200	400	125	0.1	60	70	2	150	10	−10	110				90*	7.5	40*	44	2SA545 とコンプリ
★	〃 854	富士通	PA	Si. EP	40	20	300	2.5 W (Tc=25°C)	175	1	12	25	5	100	15	−30	40	P_o=0.75 W (f=175MHz, V_{CE}=12V)			800*	2.5	20*	84 B	
★	〃 855	〃	〃	〃	40	30	400	3 W (Tc=25°C)	175	1	12	25	5	100	15	−30	40	P_o=0.9W (f=175MHz, V_{CE}=12V)			800*	2.5	20*	84 B	
★	〃 856	日立	RF	Si. TPa	150	150	50	300	175		20	50	6	10	6	−10					150*	2.5	25*	12 A	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC857	日立	SW. RF	Si.TMe	200	150	50	200	175	0.1	20	80	6	10	6	−10					100*	3	40	12A		
★	〃 858	三洋	RF. LN	Si.P	20	15	50	100	125	1	15	230	6	1	6	−1	NF=8dB (f=25Hz)	3000	0.7	9	140*	4	$C_c r_{bb'}$ 250ps	27		
★	〃 859	〃	〃	〃	20	15	50	100	125	1	15	230	6	1	6	−1	NF=15dB (f=25Hz)	3000	0.7	9	140*	4	$C_c r_{bb'}$ 250ps	27		
★	〃 860	〃	RF	Si.EP	15	10	30	80	125	1	10	80	6	1	6	−1					700*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 50ps	205C		
★	〃 861	日立	PA	Si.TMe	450	250	1 A	50 W (Tc=25°C)	150	1 mA	30	50	5	200	15	−200					7*	140	10	102		
★	〃 862	〃	〃	〃	650	250	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	1 mA	30	9	2	3.5 A	15	−200					7*	140	10	102		
★	〃 863	東芝	RF	Si.EP	60	45	25	175	150	1	10				10	−5	100				600*	1.5	10	117C		
★	〃 864	〃	〃	〃	40	30	25	175	150	1	10				10	−5	100				600*	1.5	10	117C		
★	〃 865	富士通	PA	Si.TP	60	40	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	5	30	70	4	1 A			P_o=4.8W (f=50MHz, V_{CC}=20V, P_i=1 W)							83		
★	〃 866	〃	〃	〃	60	35	1.5 A	5 W (Tc=25°C)	175	5	12	70	4	400			P_o=3.5W (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.5W)							97B		
★	〃 867	ソニー	PA. SW	Si.TMe	400	150	1 A	23 W (Tc=25°C)	150	100	50	80	3	100	10	−200					8*	120	12	100		○
★	〃 868	三菱	SW	Si.EP	130	70	30	200	125	0.1	25	90	6	1			t_{on}<80ns, t_{off}<90ns, t_{stg}<200ns							138B		
★	〃 869	〃	〃	〃	160	100	30	200	125	0.1	25	90	6	1			t_{on}<80ns, t_{off}<90ns, t_{stg}<200ns							138B		
★	〃 870	〃	RF. AF. LN	〃	30	25	30	200	125	0.1	25	160	6	0.1	6	−0.1	190	50 k	1.2	3.5	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 200ps	138B		
★	〃 871	〃	〃	〃	30	25	30	200	125	0.1	25	250	6	0.1	6	−0.1	270	70 k	1.4	3.5	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 200ps	138B		
★	〃 872	富士通	PA	〃	40	20	400	3.5 W (Tc=25°C)	175	1	12	25	5	100	13.5	−30	P_o=1.3W (f=400MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=0.4W)				800*	3	20*	84C		
★	〃 873	三洋			75		1 A	500	150	100	70	60	6	50							200*		$C_c r_{bb'}$ 50ps	84B	2SA535 2SA536 とコンプリ	
★	〃 874	〃			50		1 A	500	150	100	45	60	6	50							200*		$C_c r_{bb'}$ 50ps	84B	2SA535 2SA536 とコンプリ	
★	〃 875	〃	RF. PA	Si.TP	75	75	200	500	150	10	40	100	6	50	6	−10					170*	5		84B		
★	〃 876	〃	〃	〃	50	50	200	500	150	10	40	100	6	50	6	−10					170*	5		84B		
★	〃 877	東光	SW	Si.EP	40	15	200	300	175	0.1	20	60	1	10				t_{on}<20ns, t_{off}<35ns t_{stg}<20ns						49C		
★	〃 878	〃	〃	〃	40	15	200	300	175	0.1	20	70	1	10				t_{on}<12ns, t_{off}<22ns t_{stg}<13ns						49C		
★	〃 879	〃	〃	〃	60	30	1 A	800	175	1	40	80	1	100				t_{on}<70ns, t_{off}<100ns t_{stg}<50ns						84B		
★	〃 880	〃	〃	〃	60	50	1 A	800	175	1	40	80	1	100				t_{on}<70ns, t_{off}<100ns t_{stg}<50ns						84B		
★	〃 881	日電	RF. PA	Si.E	60	45	200	400	125	0.1	45	70	2	150	10	−10	110				200*	5.5	25	44		
	〃 882	芝電	RF. Conv Osc	Si.EP	150	100	2 A	25 W (Tc=25°C)	150	50	30				5	−0.5A	50				30*	45	7	102		
	〃 883	〃	〃	〃	90	70	2 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	30				5	−0.5A	50				30*	45	7	102		
	〃 884	〃	PA	Si.TMe	80	80	2 A	15 W (Tc=25°C)	150	100	30	60	5	500	5	−200					30*	45	7	153		
	〃 885	〃	SW	〃	330	100	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	50	30	35	5	1 A				t_r<2 μs, t_f<3 μs t_{stg}<6 μs						102		
	〃 886	〃	〃	〃	270	90	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	50	30	35	5	1 A				t_r<2 μs, t_f<3 μs t_{stg}<6 μs						102		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SC887	芝電	SW	Si. TMe	210	80	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	50	30	35	5	1 A				t_r< 2 μs, t_f< 3 μs t_{stg}< 6 μs						102	
	〃 888	〃	〃	〃	150	70	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	30	35	5	1 A				t_r< 2 μs, t_f< 3 μs t_{stg}< 6 μs						102	
	〃 889	三菱	RF. AF. LN	Si. EP	90	60	7 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	30	35	5	1 A				t_r< 2 μs, t_f< 3 μs t_{stg}< 6 μs						102	
★	〃 890	日電	PA	Si. E	40	20	400	750	175	1	20	>20	10	100	10	−50	40	P_o=1.3W (f=500MHz, P_i=0.3W, V_{CC}=13.5V)						84C	
★	〃 891	〃	〃	〃	40	20	600	10.3W (Tc=25°C)	175	5	20	>15	10	500	10	−100	40	P_o= 4 W (f=500MHz, P_i= 1 W, V_{CC}=13.5V)						115	
★	〃 892	〃	〃	〃	40	20	1.2A	17.7W (Tc=25°C)	175	10	20				10	−300	40	P_o= 8 W (f=500MHz, P_i= 1 W, V_{CC}=13.5V)						115	
	〃 893	富士通	RF	Si. TMe	100	60	500	12 W (Tc=25°C)	175	1	30	100	4	50	4	−50					20*	10	30	97B	
★	〃 894	ソニー	RF. SW	Si. DB	25	13	100	100	120	0.2	25	100	3	1	6	−2					200*	2.4	$C_c r_{bb'}$ 120ps	38	
★	〃 895	〃	PA. SW	Si. TMe	150	90	2.5 A	23.7 W (Tc=25°C)	150	50	50	120	3	100	10	−200					20*	145	24	102	
★	〃 896	日電	RF	Si. E	55	30	200	300	175	1	30				10	−5	70				200*	3.5	35*	315	
★	〃 897	日立	PA	Si. T	150	90	7 A	60 W (Tc=25°C)	150	1 mA	30	60	5	1 A	5	−1 A					15*	140		102	2SA757 とコンプリ
★	〃 898	〃	〃	〃	150	110	7 A	80 W (Tc=25°C)	150	1 mA	30	50	5	1 A	5	−1 A					15*	140		102	2SA758 とコンプリ
★	〃 899	日電	RF. AF. LN	Si. E	50	25	50	250	125	0.1	15	110	3	0.5	6	−1	140	4000	0.65	8.5	250*	1.8	$C_c r_{bb'}$ 70ps	138	
★	〃 900	〃	RF. LN	〃	30	35	30	250	125	0.1	25	400	3	0.5	6	−1					100*	3.5	50*	138	
★	〃 901	松下	PA	Si. TMe	200	200S	5 A	50 W (Tc=70°C)	150	15mA	150	25	4	5 A	10	−500		t_r< 3 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs			50*			102	
★	〃 901A	〃	〃	Si. EP	250	250S	5 A	50 W (Tc=70°C)	150	15mA	150	25	4	5 A	10	−500		t_r< 3 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs			50*			102	
★	〃 902	富士通	SW	Si. TMe	150	80	10A	75 W (Tc=25°C)	175	15	30	50	4	5 A				t_r< 2 μs, t_f<1.5 μs t_{stg}<2.5 μs						102	
★	〃 903	三菱	PA	Si. EP	35	30	300	200	125	1	25	100	2	150	6	−10					150*	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	
★	〃 904	〃	〃	〃	50	45	300	200	125	1	25	100	2	150	6	−10					150*	10		138B	
★	〃 905	〃	〃	〃	65	60	300	200	125	1	25	80	2	150	6	−10					150*	10		138B	
★	〃 906	富士通	PA. SW	〃	50	30	500	600	175	0.5	12	160	4	10	6	−1		t_r<0.08 μs, t_f<0.15 μs t_{stg}<0.8 μs			70*			89	
★	〃 907	日立	RF. SW. AF	Si. DB	40	30	100	200	175	0.5	20	200	1	10	6	−1		4000	2	10	240*	1.7	150	12A	
★	〃 907A	〃	〃	〃	60	40	100	200	175	0.5	20	120	1	10	6	−1		4000	2	10	240*	1.7	150	12A	
	〃 908	三菱	PA	Si. EP	40	40R	500	860	175	50	15	50	10	100				P_o=1.2W (f=500MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.4W)						84B	
★	〃 909	〃	〃	〃	40	40R	500	7 W (Tc=25°C)	200	50	15	50	10	100				P_o=3.5W (f=500MHz, P_i= 1 W, V_{CC}=13.5V)						113	
★	〃 910	〃	〃	〃	40	40R	1 A	10 W (Tc=25°C)	200	100	15				10	−100	50	PG = 5 dB (f=500MHz, P_i= 2 W, V_{CE}=13.5V)						113	
★	〃 911	〃	〃	〃	40	40R	500	1.7W	175	50	15	50	10	100				P_o=1.4 W (f=500 MHz, V_{cc}=13.5 V, P_i=0.3 W)						271	○
★	〃 912	〃	RF. Conv. Mix Osc. SW	〃	30	25	100	150	150	0.1	25	90	6	10	6	−1	80	2500	0.35	15	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	8 A	
	〃 913	富士通, 沖 日電, 日立	SW	〃	40	35	300	300	175	0.2	20	70	1	30		t_{on}<45ns, t_{off}<42ns t_{stg}<27ns						2.5		49C	
	〃 914	〃	〃	〃	40	35	300	300	175	0.2	20	70	1	30		t_{on}<80ns, t_{off}<86ns t_{stg}<65ns						2.5		49C	○

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SC915	富士通,神日電,日立	SW	Si. EP	30	20	300	300	175	0.2	20	70	1	30			t_{on}<45ns, t_{off}<42ns t_{stg}<27ns					2.5		49C		○
	〃 916	〃	〃	〃	100	70	1.5 A	2 W	175	10	80	70	1	400			t_{on}<63ns, t_{off}<210ns t_{stg}<190ns					30		83		
★	〃 917	日立	RF	Si. P	40	40	50	300	175	10	40	40	10	10	10	−10					800*	1	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	56C		
★	〃 918	ソニー	〃	Si. DB	20	20	30	188	100	0.2	15	80	10	4	10	−4	h_{fe}=12dB (f=100 MHz)					0.7	$C_c r_{bb'}$ 10ps	205C		
★	〃 919	日電																								
★	〃 920	〃	RF. Conv. Mix. Osc. LN	Si. E	50	25	30	150	150	0.1	15	75	3	0.5	6	−1	NF=2.5dB (f=1 MHz)				250*	1.6	$C_c r_{bb'}$ 30ps	23		
★	〃 921	〃	RF. Conv. Mix. Osc.	〃	25	12	10	100	150	0.1	12	65	3	0.5	6	−1					650*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 9 ps	23		
★	〃 922	〃	〃	〃	30	20	20	250	125	0.1	20	80	6	1	6	−1					650*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 15ps	138		
★	〃 923	〃	RF. AF	〃	40	35	100	250	125	0.05	40	500	3	0.5	6	−1					100*	3.5	50*	138	2SA641 とコンプリ	
★	〃 924	〃	〃	Si. EP	30	15	50	250	125	0.1	15	100	3	0.5	6	−1	130	3800	0.6	8	250*	1.8	$C_c r_{bb'}$ 20ps	138		
★	〃 925	〃	RF. AF. SW	〃	30	15	50	250	125	0.1	30	130	12	2	12	−2	140	2300	3.5	45	250*	1.8	50	138		
★	〃 926	ソニー	RF. SW	Si. DB	115	115	100	100	120	0.2	115	50	3	1	10	−2					160*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 40ps	38		○
★	〃 927	三洋	RF. LN	Si. TP	30	25	20	150	125	1	25	80	6	1	6	−3					500*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 3.0 ps	205C		
★	〃 928	〃	RF	〃	30	15	20	150	125	1	25	80	6	1	6	−3					500*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 3 ps	205C		
★	〃 929	〃	RF. Conv. LN	Si. EP	30	20	30	250	125	1	10	100	6	1	6	−1					300*	C_{re} 1.3	$C_c r_{bb'}$ 20ps	138		
	〃 930	〃	RF	〃	30	20	30	250	125	1	10	80	6	1	6	−1					300*	C_{re} 1.3	$C_c r_{bb'}$ 20ps	138		
★	〃 931	〃	PA	Si. TMe	50	50	3 A	10 W (T_c=25°C)	125	1 mA	45	70	2	1 A	5	−0.5A					120*	100	35	120		
★	〃 932	〃	〃	〃	30	20	3 A	10 W (T_c=25°C)	125	1 mA	25	70	2	1 A	5	−0.5A					120*	100	35	120		
★	〃 933	〃	AF	Si. EP	50	30	300	300	125	1	45	150	5	20	6	−5					300*	5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	138		
★	〃 934	〃	〃	〃	20	15	300	300	125	1	15	150	5	20	6	−5					300*	5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	138		
★	〃 935	日立	PA	Si. T	300	300	2.5 A	50 W (T_c=25°C)	150	I_{CBX} 1mA	300	14	10	300										102		
★	〃 936	〃	〃	〃	1000	500	1 A	22 W	125	I_{CBX} 1mA	1000	45	10	100										102		○
★	〃 937	〃	〃	〃	1200	500	2.5 A	22 W (T_c=25°C)	125	I_{CBX} 1mA	1200	8	10	2.5A			t_f<1.2μs							102		
★	〃 938	日電	RF	Si. E	60	60	200	250	125	0.1	60	80	1	50	10	−10					90*	7.5	40*	138		
★	〃 939	〃	PA. SW	Si. EMe	150	150S	5 A	50W (T_c=25°C)	150	2mA	60	70	5	5 A	10	−200					20*	150	20*	102		
★	〃 940	〃	〃	SiEMe	200	200S	5 A	50W (T_c=25°C)	150	2mA	90	40	5	5 A	10	−200		t_f< 1 μs			20*	150	20*	102		
	〃 941	東芝	RF. LN	Si. E	35	30	100	400	125	0.1	20	40~240	12	2	10	−2	NF=2 dB (f=1 MHz, I_E=−1mA)				120*	C_{re} 2.2	$C_c r_{bb'}$ 30ps	138		
★	〃 942	富士通	RF	Si. EP	20	15	20	300/unit	175	0.5	10				6	−2	70				700*	1.3	80*	122C	直結2段 2素子複合	
	〃 943	日電	〃	Si. E	60	40	200	300	150	0.5	40	150	1	10	10	−10					250*	3.4	40	49C	2SA603 とコンプリ	
	〃 944	〃	RF. AF. SW	〃	60	40	100	250	125	0.1	40	180	10	2	6	−10					250*	2.2	$C_c r_{bb'}$ 40ps	138		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC945	日電	RF. AF	Si. E	60	50	100	250	125	0.1	60	200	6	1	6	−10					250*	3	25*	138	2SA733とコンプリ
★	〃 946	〃																							
★	〃 947	松下	RF. Conv. Mix. Osc. PA	Si. P	25	20	15	150	175	100	25	20	10	2	10	−3					650*	Cre 0.33ps	20	50C	
★	〃 948	〃	RF	〃	25	20	15	150	175	100	25	24	10	3	10	−3					800*	Cre 0.33ps	30	50C	
★	〃 949	新日無	RF. AF. LN	Si. EP	45	40	50	200	125	0.05	20	150	6	1	6	−0.3	200	12k	1.4	4.3	200*	2	$C_c r_{bb'}$ 60ps	138	2SA763とコンプリ
★	〃 950	〃	RF. AF	〃	30	25	100	300	125	0.1	20	100	6	1	10	−2					100*	4	$C_c r_{bb'}$ 75ps	138	2SA573とコンプリ
★	〃 951	〃	〃	〃	60	50	100	300	125	0.1	20	100	6	1	10	−2					100*	4	$C_c r_{bb'}$ 75ps	138	2SA574とコンプリ
★	〃 952	〃	RF	〃	100	90	100	300	125	0.1	70	100	6	1	10	−2					100*	4	$C_c r_{bb'}$ 75ps	138	2SA575とコンプリ
★	〃 953	〃	〃	〃	30	30	200	600	125	0.5	20	80	1	100	10	−5					90*	5	$C_c r_{bb'}$ 50ps	31	2SA576とコンプリ
★	〃 954	〃	RF. PA	〃	60	60	400	600	125	0.5	20	100	1	100	10	−5					90*	5	$C_c r_{bb'}$ 50ps	31	2SA577とコンプリ
★	〃 955	〃	RF	〃	20	15	50	150	125	1	10	100	6	1	6	−2					150*	2	$C_c r_{bb'}$ 250ps	29	
★	〃 956	〃	RF. AF	〃	50	40	50	150	125	0.1	20	250	6	1	6	−1		30k	6	30	200*	2	$C_c r_{bb'}$ 200ps	29	
★	〃 957	ソニー	RF	Si. DB	30	30	100	360	100	0.3	15	30	3	1	10	−10		h_{fe}=16dB (f=100MHz)				1.5	$C_c r_{bb'}$ 10ps	206C	
★	〃 958	日電																							
★	〃 959	〃	PA	Si. E	120	80	700	700	150	3	80	80	5	200	10	−100					>50*	<50	35*	84B	2SA606とコンプリ
★	〃 960	〃	〃	〃	120	80	700	1 W	150	3	80	80	5	200	10	−100					>50*	<50	35*	97B	2SA607とコンプリ
	〃 961	芝電	PA	Si. TMe	120	90	7 A	60W (T_c=25°C)	150	100	30	60	4	1 A	5	−500					13*	350	5	102	
	〃 962	〃	〃	〃	100	80	7 A	60W (T_c=25°C)	150	100	30	60	4	1 A	5	−500								102	
★	〃 963	富士通	RF	Si. EP	35	25	50	250	175	2	12	70	6	1	6	−1	100				200*	2	50*	55C	
★	〃 964	〃	〃	〃	35	25	50	250	175	2	12	100	6	1	6	−1		4000	5	20	200*	2	50*	55C	
★	〃 965	〃	RF. SW	〃	45	30	100	250	175	0.5	12	130	6	1	6	−1	t_r<80ns, t_f<100ns t_{stg}<200ns				200*	2	50*	55C	
★	〃 966	〃	RF. AF. LN	〃	30	20	200	500	175	0.5	12	160	4	10	6	−1	120	3500	0.1	5	70*	10	80	55C	
★	〃 967	〃	RF. AF. PA	〃	30	20	500	500	175	1	12	160	4	10	6	−1	120	3500	0.1	5	70*	10	70	55C	
★	〃 968	〃	RF. PA	〃	50	30	500	500	175	1	12	160	4	10	6	−1					70*	10	40	55C	
★	〃 969	〃	RF. AF. LN	〃	50	30	200	500	175	0.1	12	160	4	10	6	−1		3500	0.1	5	60*	10	80	55C	
★	〃 970	〃	RF. SW	〃	50	30	500	500	175	0.5	12	160	4	10	6	−1	t_r<80ns, t_f<150ns t_{stg}<800ns				70*	10	70	55C	
★	〃 971	〃	RF. PA	〃	50		500	1 W	175	1	12	160	4	10	6	−1					70*	10	40	90	
★	〃 972	三洋	〃	〃	70	70	400	600	150	10	70	40~200	4	200	4	−10					80*			84B	
★	〃 973	三菱	PA	〃	40	40R	500	7 W (T_c=25°C)	175	50	15	50	10	100			P_o= 4 W (f=500MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=1W)							126	
★	〃 974	〃	〃	〃	35	35R	1 A	10 W (T_c=25°C)	200	100	15	50	10	100			P_o= 6 W (f=500MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=2W)							126	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SC975	三菱	PA	Si. EP	35	35R	1.5A	17 W (Tc=25°C)	175	200	15	50	10	100										126		○
★	〃 976	〃	〃	〃	55	35	400	5 W (Tc=25°C)	175	100	30	50	28	20				P_o=1.1W (f=1 GHz, V_{cc}=28 V, P_i=0.3 W)						126		
★	〃 977	〃	〃	〃	55	35	600	10 W (Tc=25°C)	175	300	30	50	28	50				P_o=3 W (f=1 GHz, V_{cc}=28 V, P_i=0.75W)						126		
★	〃 978	〃	〃	〃	55	35	1.2A	18 W (Tc=25°C)	175	500	30	50	28	50				P_o=5.5W (f=1 GHz, V_{cc}=28 V, P_i=2 W)						126		
	〃 979	東芝	RF.SW	Si. E	70	50	100	300	175	0.1	70	40~240	1	10	10	−10					250*	3		49C	2SA499 とコンプリ	○
	〃 980	〃	〃	〃	70	50	100	400	125	0.1	50	70~240	1	10	10	−10					250*	3	30	138		○
★	〃 981	〃	PA	〃	100	100R	5 A	25W (Tc=25°C)	150	10	40	70	1.5	5 A	5	−500					10*	80	10	99		
	〃 982	〃	AF.SW	〃	40	40	300	400	125	0.1	40	>5000	5	10										138	ダーリントン	
★	〃 983	〃	〃	Si. TP	250	150	50	600	150	0.1	30	40~240	5	10	30	−10					120*	<5.5	25	131		
★	〃 984	日立	〃	Si.EPa	50	50	500	350	175	0.5	20	80	3	10	3	−10					230*	5	24*	12A	2SA565 とコンプリ	
★	〃 985	日電	RF. LN	Si. E	20	15	40	200	150	0.5	10	80	5	15	5	−15	NF = 5.3dB (f= 2 GHz, 5 V, − 4 mA)				3200*	0.6	$C_c r_{bb'}$ 1 ps	26		○
★	〃 986		RF	〃	35	20	200	3.5W (Tc=25°C)	200	1	20	100	15	70	15	−70					2500*	1	$C_c r_{bb'}$ 3 ps	146A		
★	〃 987	〃	〃	〃	20	15	30	150	150	0.5	10	80	10	10	10	−10	NF = 8 dB (f= 4 GHz, 10V, − 3 mA)				4500*	0.35	$C_c r_{bb'}$ 0.6ps	26		○
	〃 988	〃	〃	〃	20	15	30	200	200	0.1	10	100	10	10	10	−10	NF<2.5dB (f=500MHz, 10V, − 3 mA)				3000*	C_{rc} 0.5	30*	50C		○
★	〃 989	〃	〃	〃	20	12	50	300	200	0.5	10	80	1	30	3	−15					3000*	0.9	30*	25		
★	〃 990	〃	PA	〃	50	25	2 A	24 W (Tc=25°C)	175	10	20	40	10	1 A	10	−300	P_o=15W (f=400MHz, V_{CC}=18V, P_i=4.3W)				400*	25		116		
★	〃 991	東芝	〃	Si.EP	36	36R	400	600	175	1	15	30	3	100	10	−50	P_o=1.3W (f=175MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.1W)				500*	5	10	84B		
★	〃 992	〃	〃	〃	36	36R	600	600	175	1	15	30	3	100	10	−50	P_o=2.5W (f=175MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.5W)				500*	5	10	84B		
★	〃 993	富士通	RF	〃	25	15	200	200	175	0.05	10				6	−1	80				400*	3.5	50*	46C		
	〃 994	東芝	RF. PA	〃	36	15	100	600	175	1	15	20~400	3	100	10	−10					500*	3.8		84B		
★	〃 995	〃	RF. PA	Si. TP	300	300	150	800	150	0.1	100	25~400	10	50	10	−30					100*	4.2	10	84B		
★	〃 996	〃	〃	〃	300	300	150	1.2W	150	0.1	100	25~400	10	50	10	−30					100*	4.2	10	97B		
★	〃 997	〃	RF	Si. P	40	30	25	150	150	0.025	10	70	10	4	10	−4					600*	1.5		117C		
	〃 998	〃	PA	Sj. EP	40	40R	400	600	175	1	15	>20	5	50	5	−50					550*	6.5		84B		
★	〃 999	〃	RF. PA. SW	Si. TMe	1500	700R	1.5A	50 W (Tc=25°C)	150	10	500	50	15	150	15	−200					1	70	10	102		○
	〃 1000	〃	LN	Si. E	60	50	150	400	125	0.1	60	200~700	6	2	6	−1	NF< 2 dB (6 V, 0.1mA, 100Hz)				80*	6		138	2SA493 とコンプリ	
	〃 1001	〃	RF. PA	Si. EP	40	20	500	5 W (Tc=25°C)	175	1	15	>20	5	100	10	−50	P_o=1.2W (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=0.3W)				700*	6.5	25*	84B		
★	〃 1002	〃	〃	〃	36	18	1 A	10 W (Tc=25°C)	175	20	15	60	2	200	12.6	−100	P_o= 3 W (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i= 1 W)				700*	10	20*	84B		
★	〃 1003	〃	〃	〃	36	18	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	50	15	50	2	400	12.6	−200	P_o= 6 W (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=2.5W)				350*	20	10*	111		
★	〃 1004	〃	PA	Si. TMe	1100	700R	500	50 W (Tc=25°C)	150	10	500	30~160	15	150	15	−200					5.5*	40		102		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC1004A	東芝	PA. SW	Si.TMe	1500		500	50 W (Tc=25°C)	150	10	500	30~160	15	150	15	−200					5.5*	40	10	102		
★	〃 1005	〃	PA	〃	1100	600	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	10	500	12	15	4 A	15	−500					3*	150	5	102		○
	〃 1006	日電	RF. AF	Si.E	50	40	30	300	150	0.05	30	600	3	1	6	−1		15k	1.5	35	90*	3.5	50*	49C	2SA579とコンプリ	
	〃 1007	〃	RF. SW	〃	60	40	20	300	150	0.1	40	150	1	10	10	−10					250*	3.4	30*	49C		
	〃 1008	〃	RF	〃	80	60	700	800	150	0.1	60	160	2	50	10	−50					75*	17	25*	84B	2SA708とコンプリ	○
★	〃 1009	〃	RF. Conv. Mix. Osc. LN	〃	50	25	50	150	125	0.1	15	80	3	0.5	6	−1		NF 2.5dB (f=1MHz, 6V, 0.5mA)			250*	2	$C_c r_{bb'}$ 25ps	176		
	〃 1010	〃	AF. LN	〃	50	40	30	300	150	0.05	30	550	3	1	6	−1		15k	1.5	35	90*	3.5	50*	49C	2SA578とコンプリ	
★	〃 1011	三菱	PA	Si.EP	40	20	750	8.6W (Tc=25°C)	175	100	15	50	10	100			P_o=3 W (f=150 MHz, V_{cc}=15 V, P_i=250 mW)							271		
★	〃 1012	松下		Si.TP	165	165R	60	2.5W (Tc=25°C)		2	12	60	20	40	10	−3	35	300	0.4	2.7	100*		$C_c r_{bb'}$ 60ps	84B		○
★	〃 1013	三菱	SW. PA	Si.EP	35	20	1.5A	7 W (Tc=25°C)	150	1	25	80	4	500			t_{on}<0.2μs, t_{off}<1.2μs t_s<1μs							132	2SA623とコンプリ	
★	〃 1014	〃	〃	〃	50	40	1.5A	7 W (Tc=25°C)	150	1	25	70	4	500			t_{on}<0.2μs, t_{off}<1.2μs t_s<1μs							132	2SA624とコンプリ	
★	〃 1015	〃	PA	〃	35	18	3 A	33 W (Tc=25°C)	175	500	15	50	10	100			P_o=14W (f=450 MHz, V_{cc}=13.5 V, P_i=6 W)							126		
★	〃 1016	〃	〃	〃	40	40R	500	2 W	200	50	15	50	10	100			P_o=1.3W (f=500 MHz, V_{cc}=12 V, P_i=0.3mW)							271		
★	〃 1017	〃	〃	〃	75	35	1 A	4 W (Tc=25°C)	125	10	30	50	10	100			P_o=60mW (f=27 MHz, Ic=25 mA, V_{cc}=12 V)							132		
★	〃 1018	〃	〃	〃	75	35	1 A	4 W (Tc=25°C)	125	10	30	50	10	100			P_o=1.4W (f=27 MHz, P_i=75mW, V_{cc}=12 V)							132		
★	〃 1019	〃	〃	〃	60	35	4 A	40W (Tc=25°C)	175	1mA	30	50	10	100			P_o=28W (f=500MHz, V_{cc}=28V, P_i=20W)							188		
★	〃 1020	〃	〃	〃	60	35	8 A	70W (Tc=25°C)	175	2mA	30	50	10	100			P_o=45W (f=500MHz, V_{cc}=28V, P_i=20W)							188		
★	〃 1021	〃	〃	〃	60	40	6 A	60 W (Tc=25°C)	175	2 mA	30	50	10	100			P_o=45 W (f=90 MHz, V_{cc}=28 V, P_i=5 W)							127		
★	〃 1022	〃	〃	〃	60	40	6 A	60 W (Tc=25°C)	175	2 mA	30	50	10	100			P_o=45 W (f=150 MHz, V_{cc}=28 V, P_i=10W)							127		
★	〃 1023	富士通	RF. Conv. Mix. Osc.	Si.P	25	20	25	150	125	2	12	40	6	1	6	−2					200*	1.8		138		
★	〃 1024	三洋	PA	Si.TMe	60	50	3 A	25W (Tc=25°C)	150	1 mA	55	25~200	2	1 A										99		
★	〃 1025	〃	〃	〃	200	120	3 A	25W (Tc=25°C)	150	1 mA	180	40~320	2	500	5	−500					8*	100		99		
★	〃 1026	富士通	RF. Conv.	Si.P	25	20	25	150	125	2	12	70	6	1	6	−2	NF=2.5dB (f=1MHz, 6V, 1mA)						70*	138		
★	〃 1027	三洋	SW	Si.Me	250	80	6 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	30	>9	2	5 A										102		
★	〃 1028	日電																								
★	〃 1029	〃																								
	〃 1030	日立	PA	Si.T	150	80	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	1 mA	30	80	5	1 A	5	−1 A					10*	180		102	2SA756とコンプリ	
	〃 1031	日電	SW	Si.TMe	300	300	2 A	30 W (Tc=25°C)	175	5	150	220	10	500	10	−100		t_{on}<5μs, t_{off}<15μ t_{stg}<5μs			15*			99		
★	〃 1032	富士通	RF	Si.P	25	20	25	150	125	2	12	100	6	1	6	−2					200*	1.8	70*	138		
★	〃 1033	松下	RF. AF	Si.TP	200	150	25	300	175	2	12	>30	10	5	10	−3	38	300	0.4	2.9	135*	3.3	$C_c r_{bb'}$ 60pls	49C		○

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1034	ソニー	PA. SW	Si. TMe	1100	1100S	1 A	25W (Tc=25°C)	150	5 mA	800	18	3	750	10	−200					5 *	95	$C_c r_{bb'}$ 220ps	100	
★	〃 1035	三洋	LN	Si. TP	30	15	20	150	150	1	25	100	6	1	6	−3	NF=6 dB (f=800MHz, 11V, 2mA)				700 *	0.7	$C_c r_{bb'}$ 2.5ps	205C	
★	〃 1036	〃	RF	〃	30	15	20	150	150	1	25	100	6	1	6	−3					700 *	0.7	$C_c r_{bb'}$ 2.5ps	205C	
★	〃 1037	日電	PA	Si. E	60	40	4 A	50W (Tc=25°C)	175	1 mA	30	50	10	1 A			P_o=33W (f=160MHz, V_{CC}=28V, P_i=10W)							111	
★	〃 1038	〃	〃	〃	40	20	150	3.75W (Tc=25°C)	175	50	20	15~200	10	70	10	−70	P_o=800mW (f=2.3GHz, V_{cc}=18V, P_i=250mW)				2000 *	2.5		129	
★	〃 1039	〃	〃	〃	40	20	250	7.5W (Tc=25°C)	175	100	20	15~200	10	100	10	−100	P_o=1.4W (f=2.3GHz, V_{cc}=18V, P_i=630mW)				2000 *	4		129	
★	〃 1040	〃	〃	〃	45	25	1.2A	15W (Tc=25°C)	175	1 mA	30	15~200	10	1 A			P_o=8 W (f=500MHz, V_{cc}=18V, P_i=2W)							184	
	〃 1041	〃	〃	〃	40	20	150	3.75W (Tc=25°C)	175	50	20	15~200	10	70	10	−70	P_o=900mW (f=2GHz, V_{cc}=18V, P_i=250mW)				2000 *	2.5		129	
	〃 1042	〃	〃	〃	40	20	250	7.5W (Tc=25°C)	175	100	20	15~200	10	100	10	−100	P_o=1.6W (f=2GHz, V_{cc}=18V, P_i=630mW)				2000 *	4		129	
	〃 1043	〃	RF. LN	〃	45	25	300	6 W (Tc=25°C)	175	0.1	30	80	10	100	15	−50	P_G=15dB (f=500MHz, 50mA) NF=3.5dB (f=200MHz, 50mA)				2200 *	2.5		129	
	〃 1044	〃	RF	〃	45	25	30	250	200	50nA	30	100	6	6	6	−6	G_P=22dB (f=200MHz)				1000 *	NF=3dB (f=200MHz)		50C	
★	〃 1045	三洋	RF.PA	Si. T	1000	550	1 A	25W (Tc=25°C)	125	5	100	25~200	15	200										102	
★	〃 1046	〃	PA	Si. TMe	1000	400	3 A	25W (Tc=25°C)	150	100	100	8	5	2 A	5	−100	t_f<1.5μs				4 *	150	35	102	
	〃 1047	松下	RF	Si. EP	30	20	15	400	150	10	30	120	6	1	6	−1					650 *	Cre 0.8pF	30	138	
★	〃 1048	三洋	〃	Si. Me	200	200	50	600	150	10	100	90	10	25	10	−10					120 *	3.5		84B	
★	〃 1049	〃																							
★	〃 1050	〃	PA	Si. TMe	300	300	1 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	150	90	5	300	5	−300					5 *	50		102	
★	〃 1051	〃	〃	〃	150	100	7 A	60W (Tc=25°C)	150	1 mA	30	90	5	1 A	5	−1 A					8 *	230		102	2SA714とコンプリ
★	〃 1052	富士通	SW	Si. EP	75	40	1 A	800	175	0.5	50	40	1	500			t_{on}<50ns, t_{off}<70ns t_{stg}<40ns							84B	
★	〃 1053	〃	〃	〃	75	45	700	800	175	0.2	40	50	1	500			t_{on}<40ns, t_{off}<60ns t_{stg}<45ns							123	
★	〃 1054	〃	RF. LN	〃	35	30	50	180	175	0.5	12	60	6	1	6	−2	NF=3dB (f=200MHz, 6V, 1mA)				700 *	1	30 *	205C	
	〃 1055	日立	PA. SW	Si. T	130	80	7 A	25 W (Tc=25°C)	175	200	30	60	4	5 A			t_{on}=0.4μs, t_{off}=4 μs t_{stg}=35μs							153	
★	〃 1056	ソニー	RF	Si. PaMe	260	260	100	750	175	1	100	150	5	3	20	−20					180 *	7		181	
★	〃 1057	富士通	PA	Si. EP	50	45R	1 A	12W (Tc=25°C)	175	500	20	50	5	500			P_o= 6.5W (V_{CC}=24V, f=700MHz, P_i=2W)				800 *	8		133	
★	〃 1058	〃	〃	〃	50	45R	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	1 mA	20	50	5	1 A			P_o=11.5W (V_{cc}=24V, f=700MHz, P_i=4W)							133	
★	〃 1059	日立			300	300X	150	8 W (Tc≦70°C)	150			60	10	50										153	
	〃 1060	〃	PA	Si. T	50	50	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	20	35~320	4	1 A	4	−500					8 *	100		267	2SA670とコンプリ
	〃 1061	〃	〃	〃	50	50	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	20	35~320	4	1 A	4	−500					8 *	100		268	2SA671とコンプリ
	〃 1062	富士通 日電	SW	Si. TMe	200	200	100	700	175	2	100	60	2	50			t_{on}<3.2μs, t_{off}<12μs t_{stg}<8μs					5		84B	
★	〃 1063	ソニー	〃	Si. DB	10	10	1 A	750	150	1	10	60	1	65			t_r<60ns, t_f<100ns t_{stg}<300ns							84C	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	r_{bb} h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1064	東光	SW	Si. EP	60	50	1 A	800	175	0.5	40	45	1	500										84B	
★	〃 1065	〃	〃	〃	90	70	1 A	800	175	0.5	40	40	3	500							400*			84B	
★	〃 1066	富士通	RF	〃	20	13	25	200	175	0.1	12				6	−2	120				800*	1.4	80*	46C	
★	〃 1067	〃	〃	〃	35	30	50	180	175	0.5	12	60	6	1	6	−2					500*	1	30*	205C	
	〃 1068	〃	〃	〃	25	20	150	600	175	0.5	20	100	10	40	10	−40					1800*	2	40*	84B	
	〃 1069	〃	SW	〃	100	80	1 A	800	175	0.5	70	40	3	500	10	−10	t_{on}<60ns, t_{off}<120ns t_{stg}<90ns				400*	<9		84B	
	〃 1070	日電	RF	Si	30	25	20	150	150	0.1	25	40~200	10	3	10	−3					900*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 3 ps	210A	
	〃 1071	富士通, 沖日電	SW	Si.EP	30	17	200	300	175	0.2	20	80	1	30			t_{on}<45ns, t_{off}<42ns t_{stg}<27ns							49C	
	〃 1072	〃	〃	〃	60	45	700	800	175	0.3	40	50	1	500			t_{on}<40ns, t_{off}<60ns t_{stg}<50ns							123	2SA717 とコンプリ
	〃 1072A	〃	〃	〃	66	56	700	800	175	0.3	40	50	1	500			t_{on}<40ns, t_{off}<60ns t_{stg}<50ns							123	
★	〃 1073	松下	PA	〃	36	18	500	2 W (T_c=25°C)	175	5	20	70	13.5	100			P_o=1.8W (f=500MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=0.4W)							142	
★	〃 1074	〃	〃	〃	36	18	1 A	10W (T_c=25°C)	175	5	20	50	13.5	200			P_o= 4 W (f=500MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=1.0W)							142	
★	〃 1075	〃	〃	〃	36	18	2 A	20W (T_c=25°C)	175	10	20	60	13.5	400			P_o= 8 W (f=500MHz, V_{CE}=13.5V, P_i= 3 W)							142	
★	〃 1076	〃	〃	〃	36	18	3 A	30W (T_c=25°C)	175	30	20	50	13.5	600			P_o=15W (f=500MHz, V_{CE}=13.5V, P_i= 6 W)							142	
★	〃 1077	東芝	〃	〃	65	35	5 A	50W (T_c=25°C)	175	10mA	20	>20	10	1 A	20	−200	P_o=42W (f=175MHz, V_{cc}=28V, P_i=1W)				150*	45		141	○
★	〃 1078	〃	〃	Si. TMe	700	500	500	20W (T_c=25°C)	150	10	500	70	15	150	15	−150					2*	40	10	99	
★	〃 1079	〃	〃	〃	150	120	12 A	100 W (T_c=25°C)	150	100	50	40~140	5	2 A	5	−2A					4*	350		102	
★	〃 1080	〃	〃	〃	110	100	12 A	100 W (T_c=25°C)	150	100	30	40~140	5	2 A	5	−2A					4*	350		102	
★	〃 1081	日電	〃	〃	40	18	2.5 A	30W (T_c=25°C)	175	1mA	30	70	10	1 A	10	−300	P_o=14W (f=500MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=5.5W)				400*			115	
	〃 1082	富士通	〃	Si. EP	50	30	500	7 W (T_c=25°C)	175	100	20	50	5	200	12	−100	P_o= 3 W η=55% (f=700MHz, V_{cc}=24V, P_i=0.5W)				1000*	5		159	
	〃 1083	〃	〃	〃	40	35	500	3 W (T_c=25°C)	175	100	20	80	5	200	12	−100	P_o=1.2W (f=175MHz, V_{cc}=12V, P_i=0.1W)				1600*	4		84B	
★	〃 1084	〃	RF. AF	〃	35	25	50	250	175	0.5	12	300	6	1	6	−1		8000	1.7	7.8	300*	2	50*	55C	
★	〃 1085	日立	RF. LN	Si. DB	30	30	100	200	125	0.1	30	160	6	2	6	−1		4000	0.3	145	230*	1.8	100*	182C	
★	〃 1086	ソニー	PA. SW	Si. TMe	1000	1000S	4 A	125 W (T_c=25°C)	120	2mA	800	12	3	2 A	10	−500					5*	175	$C_c r_{bb'}$ 450 ps	102	
★	〃 1087	富士通	PA	Si. EP	45	40R	3 A	25W (T_c=25°C)	175	1mA	20	50	5	2 A	12	−500	P_o=16W (f=700MHz, V_{cc}=24V, P_i= 5 W)				1000*	18		133	
★	〃 1088	三菱	〃	Si. TP	300	250	100	12.5W (T_c=25°C)	150	3	300	70	10	50	50	−20					40*	5	$C_c r_{bb'}$ 20 ps	180	
★	〃 1089	〃	〃	〃	300	300	100	12.5W (T_c=25°C)	150	3	300	70	10	50	50	−20					50*	3	$C_c r_{bb'}$ 20 ps	180	
	〃 1090	日電	RF	Si. E	20	12	50	300	200	0.5	10	60	1	30	5	−15					3000*	C_{rc} 0.9	30*	130	
★	〃 1091	〃																							
★	〃 1092	〃	PA	Si. E	150	120	700	800	150	1	100	90	5	100										84B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1093	日電																								
★	〃 1094	〃																								
★	〃 1095	〃	PA	Si. E	30	20	2 A	10W (Tc=25°C)	150	100	15	80	5	1 A	5	−150					60 *	60	70 *	167		
★	〃 1096	〃	〃	〃	40	30	3 A	10W (Tc=25°C)	150	1	30	100	5	1 A	5	−100					65 *	55		167	2SA634 とコンプリ	
★	〃 1097	〃	〃	〃	60	40	1 A	10W (Tc=25°C)	150	100	50	80	5	500	5	−100					60 *	60	80 *	167		
★	〃 1098	〃	PA.SW	Si.E	70	45	3 A	10W (Tc=25°C)	150	1	45	100	5	500	5	−100					60 *	40		167	2SA636 とコンプリ	○
★	〃 1099	〃	SW	Si.TMe	1200	400	4.5A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1000	25	15	3 A			t_r<2.5μs, t_f<1μs, t_{stg}<1.5μs							102		
★	〃 1100	〃	〃	〃	1100	400	4.5A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1000	25	15	3 A			t_r<2.5μs, t_f<1μs, t_{stg}<1.5μs							102		
★	〃 1101	〃	〃	〃	1100	500	1 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1000	60	15	500			t_r<10μs, t_f<2μs, t_{stg}< 2 μs							102		
★	〃 1102	〃	PA. SW	〃	300	300	100	11W (Tc=25°C)	150	100	300	90	10	10	30	−10					80 *	3.5	10	134		
★	〃 1103	〃	PA	Si.T	250	250	100	800	150	100	250	80	10	10	30	−10					80 *	4.5	30	84B		○
★	〃 1104	〃	SW	〃	300	300	700	20W (Tc=25°C)	150	100	200	80	10	400			t_r<2.5μs, t_f<2μs, t_{stg}<1.5μs							134		
★	〃 1105	〃	PA	〃	300	300	100	15W (Tc=25°C)	150	100	200	80	10	50	50	−20					20 *	5	30	134		
★	〃 1106	〃	SW	〃	350	250	2 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	80	15	500			t_r< 3 μs, t_f<3μs, t_{stg}< 2 μs							102		
★	〃 1107	サンケン	PA	Si.TMe	80	60	4 A	25W (Tc=25°C)	150	100	80	120	4	1 A	10	−200					10 *	25	26 *	268		
★	〃 1108	〃	〃	〃	100	80	4 A	25W (Tc=25°C)	150	100	100	120	4	1 A	10	−200					10 *	25	26 *	268		
★	〃 1109	〃	〃	〃	80	60	4 A	25W (Tc=25°C)	150	100	80	120	4	1 A	10	−200					10 *	25	26 *	267		
★	〃 1110	〃	〃	〃	100	80	4 A	25W (Tc=25°C)	150	100	100	120	4	1 A	10	−200					10 *	25	26 *	267		
★	〃 1111	〃	〃	〃	140	80	6 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	140	60	4	3 A	12	−500					10 *	115	12 *	102		
★	〃 1112	〃	〃	〃	160	100	6 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	160	60	4	3 A	12	−500					10 *	115	12 *	102		
★	〃 1113	〃	PA. SW	〃	120	100	6 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	120	60	4	5 A	12	−500	t_r<1.5μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs				10 *			99		
★	〃 1114	〃	PA	〃	300	250	4 A	100 W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	60	4	1 A	12	−100					10 *	50	26 *	102		
★	〃 1115	〃	〃	〃	140	80	10A	100 W (Tc=25°C)	150	1 mA	140	60	4	3 A	12	−500					10 *	165	13 *	102	2SA746 とコンプリ	
★	〃 1116	〃	〃	〃	180	120	10A	100 W (Tc=25°C)	150	1 mA	180	60	4	3 A	12	−500					10 *	165	13 *	102	2SA747 とコンプリ	○
★	〃 1117	日立	RF	Si. P	20	20	20	150	150	1	15	150	10	2	10	− 2	G_{pb}=13dB, NF=5.0dB (12V, 2mA, f=800MHz)				850 *	Cre 0.35		50C		
	〃 1118	日電	〃	Si. E	45	25	2 A	27 W (Tc=25°C)	175	2 mA	30	50	10	1 A	10	−300	P_o=14.5W (f=500MHz, V_{cc}=18V, P_i= 5 W)				400 *	30		184		
	〃 1119	〃	RF	〃	20	15	30	250	175	0.1	10	100	10	10	10	−10					4500 *	Cre 0.4	20 *	130		
★	〃 1120	東芝	PA	Si.EP	35	20	1.5A	10W (Tc=25°C)	175	5	15	40	5	500	10	−100	P_o= 4 W (f=470MHz, P_i=1W, V_{cc}=12.6V)				700 *	8	20 *	135		
★	〃 1121	〃	〃	〃	35	20	3 A	20W (Tc=25°C)	175	25	15	40	5	1 A	10	−200	P_o=8.5W (f=470MHz, P_i=3W, V_{cc}=12.6V)				500 *	20	10	135		
★	〃 1122	〃	〃	〃	35	35R	4.5A	30W (Tc=25°C)	175	100	15	40	5	1.5A	10	−100	P_o=14W (f=470MHz, P_i=6W, V_{cc}=12.6V)				400	20		135		○

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1123	ソニー	Mix	Si. DB	35	35	100	300	100	0.2	15	70	3	1	10	−5	h_{fe}=15dB (f=100MHz)				550*	2.1	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	138D	
★	〃 1124	〃	PA	Si.PaMe	140	140	1 A	950	120	1	50	160	2	100	10	−10					120*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	174	
★	〃 1125	〃																							
★	〃 1126	〃	RF. Osc	Si. DB	30	15	50	250	100	0.2	15	50	3	1	10	−8	h_{fe}=15dB (f=100MHz)				550*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 16 ps	138C	
★	〃 1127	〃	RF	Si.PaMe	180	180	100	950	120	1	100	60	5	3	10	−2					30*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 80ps	174	
★	〃 1128	〃	〃	〃	35	35	100	300	100	0.3	15	70	3	1	10	−10	h_{fe}=16dB (f=100MHz)				550*	1.6	$C_c r_{bb'}$ 7 ps	138C	
★	〃 1129	〃	〃	〃	35	35	30	300	100	0.2	15	70	10	4	10	−4	h_{fe}=12dB (f=100MHz)				400*	1	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138C	フォワードAGC
	〃 1130	オリジン	PA. SW	SiT	800	400	3.5A	80W (T_c=25°C)	150	2mA	800	15	5	2 A	10	−1A	t_{on}<1μs, t_{off}<2μs				4*	150	10	102	
	〃 1131	〃	〃	〃	600	300	3.5A	80W (T_c=25°C)	150	2mA	600	15	5	2 A	10	−1A	t_{on}<1μs, t_{off}<2μs				4*	150	10	102	
★	〃 1132	〃	〃	〃	1200		2.5A	30W (T_c=25°C)	125	1mA	1200	15	5	0.5A	10	−1A	t_{on}<1μs, t_{off}<1.2μs				3.5*	110	10	102	
★	〃 1133	〃																							
★	〃 1134	〃																							
★	〃 1135	〃																							
	〃 1136	〃	PA. SW	Si. T	200	150	30A	200W (T_c=25°C)	150	5mA	200	20	5	10A	10	−1A					9*	650	5	266	
★	〃 1137	〃																							
	〃 1138	〃	PA. SW	Si. T	800	400	30 A	200 W (T_c=25°C)	150	5mA	800	20	15	10 A	10	−1A					9*	650	5	266	
	〃 1139	〃	〃	〃	600	300	30 A	200 W (T_c=25°C)	150	5mA	600	20	5	10 A	10	−1A					9*	650	5	266	
	〃 1140	〃	〃	〃	800	400	15 A	150W (T_c=25°C)	150	3mA	800	15	5	7.5A	10	−1A	t_{on}<1.5μs, t_{off}<5μs				10*	350	10	102	
	〃 1141	〃	〃	〃	600	300	15 A	150W (T_c=25°C)	150	3mA	600	15	5	7.5A	10	−1A	t_{on}<1.5μs, t_{off}<5μs				10*	350	10	102	
★	〃 1142	〃	〃	〃	800	400	10A	125W (T_c=25°C)	150	3mA	800	15	5	5 A	10	−1A	t_{on}<1.5μs, t_{off}<3μs				4*	270	10	102	
★	〃 1143	〃	〃	〃	600	300	10A	125W (T_c=25°C)	150	3mA	600	15	5	5 A	10	−1A	t_{on}<1.5μs, t_{off}<3μs				4*	270	10	102	
★	〃 1144	〃																							
★	〃 1145	〃																							
★	〃 1146	〃																							
★	〃 1147	〃																							
★	〃 1148	〃																							
★	〃 1149	〃																							
	〃 1150	富士通	SW	Si. EP	60	50	1 A	800	175	0.5	40	50	1	500				t_{on}<35ns, t_{off}<55ns t_{stg}<50ns						123	
★	〃 1151	三菱	RF. PA	Si. EMe	900	450	1 A	50W (T_c=25°C)	125	200	500	60	10	150	15	−200					5*	65	25	102	
★	〃 1152	〃	〃	〃	300	300	2.5A	50W (T_c=25°C)	125	200	300	60	10	500	15	−200					5*	65	25	102	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SC1153	三菱	SW	Si.EMe	1200	500	2.5A	50W (Tc=25℃)	125	1mA	1200	20	10	2.5A		t_r<1.5μs, t_{stg}<2μs, t_f<3μs								102		○
★	〃 1154	〃	〃	〃	1200	500	3.5A	50W (Tc=25℃)	125	1mA	1200	20	10	3.5A		〃								102		
★	〃 1155	〃	SW.PA	Si.EP	70	60	800	7W (Tc=25℃)	150	10	25	100	4	300		t_{on}<0.2μs, t_{stg}<1μs, t_{off}<1.2μs								132	2SA645とコンプリ	
★	〃 1156	〃	〃	〃	90	80	800	7W (Tc=25℃)	150	10	25	100	4	300		〃								132	2SA646とコンプリ	
★	〃 1157	〃	〃	〃	110	100	800	7W (Tc=25℃)	150	10	25	100	4	300		〃								132	2SA647とコンプリ	
★	〃 1158	日電	Osc	Si.E	35	20	20	150	150	1	15	80	10	5	10	−5					1100*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 6ps	23		
★	〃 1159	〃	〃	〃	35	20	20	150	150	1	15	80	10	5	10	−5					1100*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 6ps	23		
★	〃 1160	〃	PA	〃	200	100	1A	15W (Tc=25℃)	150	5	200	80	5	200	10	−200					20*	30	40*	134	2SA652とコンプリ	
★	〃 1161	〃	〃	〃	200	120	1A	15W (Tc=25℃)	150	5	200	80	5	200	10	−200					20*	30	40*	134	2SA653とコンプリ	
	〃 1162	日立	〃	〃	35	35	2.5A	10W (Tc=25℃)	150	20	35	60~320	2	500	2	−200					180*	30		160	2SA715とコンプリ	
	〃 1163	松下	PA	Si.P	300	300R	100	20.8W (Tc=25℃)	150	100	300	70	10	50	10	−20					55*	8	30	236		
	〃 1164	東芝	RF	Si.EP	50	35	300	600	150	0.3	20	25~90	10	50	20	−50					1400*	2.2	<15	85B		
	〃 1165	〃	PA	〃	40	20	500	700	175	1	15	>20	5	100	10	−50		P_o=1.0W, P_i=0.3W (f=470MHz, V_{CC}=12.6V)			600*	6.5	25*	84B		
★	〃 1166	〃	〃	Si.E	70	50	200	600	150	0.1	20	100	2	50	10	−10					120*	6	10	131	2SA661とコンプリ	
★	〃 1167	〃	〃	Si.TMe	1200	1200S	1.5A	50W (Tc=25℃)	150	10	500	>10	10	500	10	−100	t_f<1μs				3*	45		102	水平偏向用	
★	〃 1168	〃	〃	Si.T	300	300	150	12.5W (Tc=25℃)	150	0.1	100	25~240	10	50	10	−30					100*	5	10	99		
	〃 1169	〃	RF	Si.EP	40	20	1A	800	175	1	15	>20	5	100	10	−50	P_o>2.5W (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=0.25W)				600*	6.5	25	97C		
★	〃 1170	〃	PA	Si.TMe	1200	500	3.5A	50W (Tc=25℃)	150	10	500	12	10	3A	10	−0.5A					4*	80	10	102		○
	〃 1170A	〃	〃	〃	1400	500	3.5A	50W (Tc=25℃)	150	10	500	12	10	3A	10	−0.5A					4*	80	10	102		
★	〃 1171	〃	〃	〃	1100	800R	1A	50W (Tc=25℃)	150	10	500	30~160	15	150	15	−200					>0.5	70		102		
★	〃 1172	〃	〃	〃	1500	600	5A	50W (Tc=25℃)	150	10	500	20	10	2A	10	−500					5*	80	10	102		○
	〃 1173	〃	RF.PA	Si.E	30	30	3A	10W (Tc=25℃)	150	1	20	70~240	2	500	2	−500					100*	35		268	2SA473とコンプリ	
★	〃 1174	日立	PA	Si.TMe	1200	500	3.5A	50W (Tc=25℃)	150	I_{CBX} 1mA	1200	8	10	3.5A	15	−200	t_f<1.2μs				4*	120	10	102		
	〃 1175	三洋	RF	Si.TP	50	50	200	400	125	10	40	100	6	50	6	−10					170*	5		138	2SA659とコンプリ	
★	〃 1176	三菱	PA	Si.EP	40	18	1A	15W (Tc=25℃)	175	100	15	30	10	100				P_o=7.5W, η=70% (f=175MHz, P_i=1.5W, V_{cc}=13.5V)						113		
★	〃 1177	〃	〃	〃	40	18	2.5A	25W (Tc=25℃)	175	1mA	15	30	10	100				P_o=17W, η=80% (f=175MHz, P_i=3.5W, V_{cc}=13.5V)						113		
★	〃 1178	〃	〃	〃	40	18	5A	35W (Tc=25℃)	175	2mA	15	50	10	100				P_o=23W, η=80% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=7W)						113		○
★	〃 1179	三洋																								
★	〃 1180	〃	RF	Si.TP	30	20	20	150	150	1	25	130	6	1	10	−2					800*	C_{re} 0.3	$C_c r_{bb'}$ 3ps	50C		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC1181	三洋	RF	Si.EP	40	40	50	300	125	1	35	15~120	6	1	6	−1					400*	C_{re} 1		205C		
★	〃 1182	〃	〃	〃	25	25	50	300	125	1	20	15~120	6	1	6	−1					400*	C_{re} 1		205C		
★	〃 1183	ソニー																								
★	〃 1184	日電	SW	Si.TMe	900	500	1 A	50W (T_c=25°C)	150	500	800	60	10	200			t_r<10μs, t_f<3.5μs, t_{stg}<1.5μs							102		
★	〃 1185	〃	〃	〃	300	250	700	50W (T_c=25°C)	150	100	200	90	10	400			t_r<2.5μs, t_f<2μs, t_{stg}<1.5μs							102		
	〃 1186	〃																								
★	〃 1187	〃	RF	Si.P	40	30	25	250	125	0.1	20	90	10	3	10	−3					700*	0.4	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138C	フォワードAGC	
★	〃 1188	〃	〃	Si.E	40	30	30	250	125	0.1	20	90	10	10	10	−10					850*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 9ps	138C		
★	〃 1189	〃	〃	〃	50	40	30	250	125	0.1	20	90	10	10	10	−10					850*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 9ps	138C		
★	〃 1190	松下	PA	Si.EP	36	18	2.5A	30W (T_c=25°C)	175	100	20	50	13.5	400			P_o=16W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=4W)				600*	17		142		
	〃 1191	〃	〃	〃	36	18	3.5A	45W (T_c=25°C)	175	0.5mA	20	50	13.5	800			P_o=27W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=8W)					50		143		
	〃 1192	〃	〃	〃	36	18	5A	60W (T_c=25°C)	175	1mA	20	60	13.5	1A			P_o=37W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=14W)				350*	100		143		
★	〃 1193	東芝	LN	〃	20	15	30	200	175	0.1	10	70	10	10	10	−10	NF=3.5dB (10V, 2mA, 2GHz)		PG=11dB (10V, 10mA, 2GHz)		4500*	0.8	20*	140		
★	〃 1194	〃																								
	〃 1195	〃	PA.SW	Si.T	200	200	2.5A	100W (T_c=25°C)	150	10	200	30~150	5	1A										102		
★	〃 1196	〃	PA	Si.EP	60	35	750	10W (T_c=25°C)	175	5	15	50	10	1A	10	−150	P_o>3W (f=700MHz, V_{cc}=28V, P_i=1W)				800*	5		135		○
★	〃 1197	〃	〃	〃	60	35	2A	30W (T_c=25°C)	175	10	15	55	10	1A	10	−150	P_o>9W (f=700MHz, V_{cc}=28V, P_i=3W)				700*	<25		135		○
★	〃 1198	〃	〃	〃	45	40R	3.5A	30W (T_c=25°C)	175	50	15	>20	10	1A	10	−150	P_o=20W (f=700MHz, V_{cc}=28V, P_i=9W)				800*	30		135		
	〃 1199	〃	RF.LN	〃	50	35	300	600	150	0.1	20	80	10	20	10	−20	NF=2.5dB (10V, −10mA, 200MHz)				1400*	2.2	$C_c r_{bb'}$ 5ps	85B		
★	〃 1200	〃	PA	〃	40	20	180	2.5W (T_c=25°C)	175	1	20	120	5	100	5	−100	P_o=1.05W (f=2GHz, P_i=0.4W, V_{cc}=18V)				1700*	2.3		136		
★	〃 1201	〃																								
★	〃 1202	〃																								
★	〃 1203	〃																								
★	〃 1204	日立	RF.AF	Si.EP	30	30	100	310	125	0.5	18	250	12	2	12	−0.1	130	16.5k	0.7	11	230*	1.8	60*	37A		
★	〃 1205	〃	RF.Mix Conv.Osc	Si.P	30	30	100	310	125	0.5	18	120	12	2	12	−2					230*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 13ps	37A		
★	〃 1206	三菱	RF.PA	Si.EP	45	30	1.7A	25W (T_c=25°C)	175	1mA	30	50	25	50			P_o=10W (f=770MHz, V_{cc}=25V, P_i=4W)							209		○
★	〃 1207	〃	〃	〃	45	30	3A	30W (T_c=25°C)	175	2mA	30	50	25	50			P_o=16W (f=770MHz, V_{cc}=25V, P_i=7W)							209		○
★	〃 1208	〃	〃	〃	36	18	10A	60W (T_c=25°C)	175	2mA	15	50	10	500			P_o=37W, η=70% (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=15W)							127		○
	〃 1209	〃	〃	〃	25	20	700	500	125	1	25	100	1	500	6	−10					150*	15	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	2SA695とコンプリ	
	〃 1210	〃	〃	〃	45	40	500	500	125	1	25	100	2	150	6	−10					130*	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	2SA696とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SC1211	三菱	RF. PA	Si. EP	65	50	500	500	125	1	25	100	2	150	6	−10					130*	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	2SA697 とコンプリ	
	〃 1212	日立	PA	Si. E	50	50	1 A	8 W (Tc=25°C)	150	5	50	60~200	4	50	4	−30					160*	30		160	2SA743 とコンプリ	○
	〃 1213	〃	AF	〃	35	35	500	400	150	0.5	20	60~320	3	10										138	2SA673 とコンプリ	○
	〃 1214	〃	〃	〃	50	50	500	600	150	0.5	20	60~320	3	10										138		
	〃 1215	松下	〃	Si.EP	30	20	50	400	150	100	30	100	10	2	10	−15					1200*	Cre 1pF	30	138		
	〃 1216	日電	SW	Si. E	40	20	200	300	150	0.1	30	140	1	10	10	−10	t_{on}<20ns, t_{off}<40ns t_{stg}<20ns				500*	3		49C		
	〃 1217	〃	RF. SW	〃	150	150	300	750	175	0.1	100	70	10	50	10	−50					250*	3.7	13*	84B	2SA712 とコンプリ	
★	〃 1218	〃	〃	〃	80	80	500	750	175	0.1	50	80	10	50	10	−50					370*	3.5	20*	84B		
★	〃 1219	富士通	RF	Si. EP	30	20	500	200	125	1	12	160	2	100	6	−1					60*	12	70*	138		
	〃 1220	〃	〃	〃	50	30	500	200	125	0.5	12	160	2	100	6	−1					60*	12	70*	138		
★	〃 1221																									
★	〃 1222	日電	RF. LN	Si. E	60	50	100	250	125	0.05	60	500	3	0.5	6	−1					100*	3.5	50	138	2SA640 とコンプリ	
★	〃 1223	三菱	PA	Si. EP	30	16	500	800	175	50	15	70	15	30			G_{pe}=13.3dB(f=220MHz, I_C=30mA, V_{cc}=13.5V)							84B		
★	〃 1224	〃	SW. PA	〃	130	120	800	7 W (Tc=25°C)	150	10	25	100	4	300			t_{on}<0.2μs, t_{off}<1.2μs t_{stg}<1μs							132	2SA698 とコンプリ	
★	〃 1225	〃																								
	〃 1226	松下	PA	Si. EP	40	32	2 A	10W (Tc=25°C)	150	1	20	120	5	1 A	5	−500					150*	50	3.3*	161	2SA699 とコンプリ	○
	〃 1227	富士通	SW	Si.TMe	300	300	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	150	50	5	5 A	5	−1A	t_{on}<1μs, t_{off}<1.5μs t_{stg}<4μs				27*			102		
	〃 1228	〃	〃	〃	500	400	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	150	15	5	5 A	5	−1A	t_{on}<2.5μs, t_{off}<2.5μs t_{stg}<4μs				15*			102		
	〃 1229	〃	〃	〃	250	200	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	100	150	50	5	5 A	5	−1A	t_{on}<1μs, t_{off}<1.5μs t_{stg}<4μs				27*			102		
★	〃 1230	〃	〃	〃	450	400	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	100	150	15	5	5 A	5	−1A	t_{on}<2.5μs, t_{off}<2.5μs t_{stg}<4μs				15*			102		
★	〃 1231	〃	〃	Si. EP	20	14	200	300	175	0.4	15	60	1	10	10	−10	t_r<10ns, t_f<15ns t_{stg}<12ns				800*	2		49C		
★	〃 1232	〃	PA	〃	45	40R	1 A	12W (Tc=25°C)	175	500	20	50	5	500			P_o=6 W (f=700MHz, V_{cc}=18V, P_i=2W)							133		
★	〃 1233	〃	〃	〃	45	40R	2 A	20W (Tc=25°C)	175	1mA	20	50	5	1 A			P_o=11W (f=700MHz, V_{cc}=18V, P_i=4W)							133		
★	〃 1234																									
★	〃 1235	三洋	RF.PA	Si. T	300	300	100	6.5W (Tc=25°C)	150	5	100	30~160	10	50	30	−20					60*	7.5		99		
★	〃 1236	東芝	LN	Si. EP	20	15	30	200	175	0.1	10	70	10	10	10	−10	NF=5.0dB (10V, 5mA, 4GHz)	PG=7.0dB (10V, 10mA, 4GHz)			6500*	0.8	20*	140		
★	〃 1237	〃	PA	Si.EMe	85	85R	2 A	10W (Tc=25°C)	150	10	20	40	5	500	5	−100	P_o=3.5W (f=27MHz, V_{cc}=12V, P_i=0.4W)				100*	30		268		
★	〃 1238	三菱	〃	Si. EP	35	25	150	5 W (Tc=25°C)	175	50	25	50	15	40			PG=11dB(f=770MHz, I_C=40mA, V_{cc}=15V)							312		
★	〃 1239	〃	〃	〃	80	40	4 A	12.5W (Tc=25°C)	175	10	30	50	10	100			P_o=3.4W(f=27MHz, P_i=0.4W, V_{cc}=12V)							97B		
★	〃 1240	〃	RF	〃	40	40	50	350	175	0.1	25	70	10	10	10	−10					600*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 5ps	138B		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC1241	東芝	PA	Si. EP	40	18	1.5A	10W (T_c=25°C)	175	100	15	>10	5	500	10	−250	P_o> 6 W (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=1W)				400*	18	7*	135		○
★	〃 1242	〃	〃	〃	40	18	3 A	20W (T_c=25°C)	175	250	15	>10	5	800	10	−500	P_o=14W (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i= 2.5W)				350*	40	5*	135		○
★	〃 1243	三菱	SW. PA	〃	25	20	1.5A	7 W (T_c=25°C)	150	1	16	100	4	500				t_{on}<0.2μs, t_{off}<1.2μs t_{stg}< 1 μs						132	2SA703 とコンプリ	
★	〃 1244	〃	SW	〃	30	25	50	200	125	1	25	60	6	1										138B		
★	〃 1245	〃																								
	〃 1246	富士通	RF	Si. EP	30	20	500	500	175	0.5	12	160	2	100	6	−1					60*	12	70*	138		
	〃 1247	〃	〃	〃	50	30	500	500	175	0.5	12	160	2	100	6	−1					60*	12	70*	138		○
★	〃 1248	日電	LN	Si. E	20	13	30	300	150	0.1	10	100	10	7	10	−7	NF=2dB (f=60MHz, 10V, 7mA)				2500*	1.2		145		
★	〃 1249	〃	RF	〃	45	30	300	2.8W 50×50×1 放熱板使用	150	1	25	80	15	65	15	−65	KF_2>53dB, KF_3>85dB (15V, 65mA, 60kHz, P_o=0dB)				1700*	3		146A		
★	〃 1250	〃	〃	〃	45	30	300	2.8W 50×50×1 放熱板使用	150	1	25	80	15	65	15	−65	KF_2>70dB, KF_3>100dB (15V, 65mA, 60kHz, P_o=0dB)				1900*	3		146B		
	〃 1251	〃	〃	〃	45	25	300	7 W (T_c=25°C)	200	0.1	30	20~200	10	50	15	−50	G_p=15dB (f=500MHz)				2200*	NF=3.5dB (f=200MHz)		129		
	〃 1252	〃	〃	〃	45	25	300	800	200	0.1	10	20~200	10	50	15	−70	G_p=17dB (f=200MHz)				1700*	NF< 4 dB (f=200MHz)		84B		
	〃 1253	〃	〃	〃	45	25	300	800	200	0.1	20	20~200	15	50	15	−50	G_p=18dB (f=200MHz)				2000*	NF= 3 dB (f=200MHz)		84B		
	〃 1254	〃	〃	〃	45	25	30	250	200	0.1	30	100	6	6	6	−6	G_p=22dB (f=200MHz)				1000*	NF= 3 dB (f=200MHz)		50C		
	〃 1255	〃	〃	〃	30	18	100	3.5W (T_c=25°C)	200	0.1	20	100	10	50	15	−50	G_p=10dB (f=2GHz)				2700*	1		129		
★	〃 1256	〃	PA	〃	36	18	800	5.5W (T_c=25°C)	200	10	20	50	10	300			P_o= 3 W (f=175MHz, V_{cc}=12V, P_i=0.3W)							84C		
	〃 1257	〃	〃	〃	36	18	1.5A	14W (T_c=25°C)	200	20	20	50	10	800			P_o= 8 W (f=175MHz, V_{cc}=12V, P_i= 1 W)							184		
★	〃 1258	〃	〃	〃	36	18	3 A	28W (T_c=25°C)	200	50	20	50	10	1.5A			P_o=14W (f=175MHz, V_{cc}=12V, P_i= 3 W)							184		
★	〃 1259	〃	〃	〃	36	18	6 A	58.3W (T_c=25°C)	200	1mA	20	50	10	3 A			P_o=30W (f=175MHz, V_{cc}=12V, P_i=10W)							149		
	〃 1260	〃	RF	〃	45	25	30	250	200	0.1	30	40~200	6	6	6	−6	G_p=14dB (f=500MHz)				2000*	NF= 3 dB (f=500MHz)		50C		
	〃 1261	富士通	LN	Si. EP	20	13	20	300	150	0.1	10	100	10	7	10	−7	NF=2dB (f=60MHz, 10V, 7mA)				2500*	1.2		147		
	〃 1262	〃	RF	〃	45	30	300	2.8W 50×50×1 放熱板使用	150	1	25	80	15	65	15	−65	KF_2>70dB, KF_3>100dB (15V, 65mA, 60kHz, P_o=0dB)				1700*	3		146A		
	〃 1263	〃	〃	〃	45	30	300	2.8W 50×50×1 放熱板使用	150	1	25	80	15	65	15	−65	KF_2>70dB, KF_3>100dB (15V, 65mA, 60kHz, P_o=0dB)				1900*	3		146A		
	〃 1264	〃	〃	〃	30	20	100	400	150	0.5	25	100	10	40	10	−40					2000*	2.3	25*	147		
	〃 1265	日電	Diff	Si. E	20	12	50	300	175	0.5	10	100	5	1	5	−15	h_{FE_1}/h_{FE_2}=0.8~1.0, ΔV_{BE}<8mV (V_{CE}=5V, I_C=1mA)				3000*	1.5	30*	189		
	〃 1266	〃	SW	〃	100	70	1.5A	2 W	175	25	80	60	1	400	1	−100	t_{on}<63ns, t_{off}<210ns t_{stg}<19ns				150*	30		83		
★	〃 1267	〃	RF	〃	45	25	300	7 W (T_c=25°C)	200	0.1	30	80	15	50	15	−50	G_p=15dB (f=200MHz)							129		
	〃 1268	〃	〃	〃	20	11	50	250	200	0.1	8	100	8	10	8	−10	G_{pe}=7.4dB (f=4GHz)				6000*	NF=4.3dB (f=4GHz)		190		
	〃 1269	〃	〃	〃	20	11	50	250	200	0.1	8	100	8	10	8	−10	G_{pe}=7.4dB (f=4GHz)				6500*	NF=4.8dB (f=4GHz)		190		
	〃 1270	〃	〃	〃	20	11	50	250	200	0.1	8	100	8	10	8	−10	G_{pe}=7.4dB (f=4GHz)				6500*	NF=5.5dB (f=4GHz)		190		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC1271	日電	RF	Si. E	20	10	30	250	200	0.05	8	100	8	10	8	−10					6000*	C_{rc} 0.4		190		○
★	〃 1272	〃	〃	〃	20	15	100	1W	200	50nA	15	80	10	40	10	−40	G_{pe}=4dB (f=4GHz)				4000*	C_{rc} <2		190		
	〃 1273	〃	〃	〃	20	15	100	1 W (T_c=25°C)	175	50nA	15	80	10	40	10	−60	G_{pe}=4dB (f=4GHz)							190		
	〃 1274	〃	SW	〃	40	35	300	300	175	0.25	20	70	1	30	8	−10	t_{on}<80ns, t_{off}<86ns t_{stg}<65ns				350*	2.5		49C		
	〃 1275	〃	RF	〃	30	14	50	250	200	0.1	15	80	10	10	10	−10	G_p=15dB (f=500MHz) NF=3dB (f=500MHz, 3mA)				2000*	1.1		50C		
	〃 1276	〃	RF. SW	〃	40	15	100	200	125	0.1	30	120	1	10	10	−10	t_{on}<20ns, t_{off}<40ns t_{stg}<20ns				600*	3	60*	138		
	〃 1277	〃	RF	〃	60	40	500	250	125	0.5	30	140	2	100	10	−20					60*	20	30*	138		
	〃 1278	〃	RF. SW	〃	150	130	50	250	125	0.1	100	120	3	15	10	−10					150*	4.5	15	138	2SA638とコンプリ	
	〃 1279	〃	〃	〃	180	160	50	250	125	0.1	100	120	3	15	10	−10					150*	4.5	15	138	2SA639とコンプリ	
	〃 1280	〃	RF	ダーリントン Si. E	15	15	300	250	125	0.1	10	20,000	5	100	10	−10					180*	5	220*	138	2SA713とコンプリ	○
★	〃 1281	沖	〃	Si. P	20	16	20	300	175	0.1	15	200	1	10μA	5	−1					120*	2	60*	49C		
★	〃 1282	〃	〃	〃	70	40	20	300	175	0.1	15	73	1	2	5	−1					120*	2	60*	49C		
★	〃 1283	〃	〃	〃	110	60	20	300	175	0.1	15	73	1	2	5	−1					120*	2	60*	49C		
★	〃 1284	三洋	Osc	Si.EP	30	20	50	200	125	0.1	20	25~200	6	1	6	−1					700*	C_{rc} 0.92		138		
★	〃 1285	〃	RF. AF	Si	40	30	100	200	125	1	35	200	6	1	6	−1	180	2000	0.8	12	140*	3	$C_c r_{bb'}$ 200ps	138		
★	〃 1286	〃																								
★	〃 1287	〃																								
★	〃 1288	沖	RF. SW	Si. EP	7	7	60	200	175	0.5	6	50	1	20	4	−20	t_d<600ps, t_f<650ps t_r<650ps				4500*	1	50*	128		
★	〃 1289																									
★	〃 1290	沖	PA	Si. EP	40	20	200	750	175	0.5	20	70	10	100	10	−50					1500*	2	35*	84B		
★	〃 1291																									
★	〃 1292	三菱	PA. SW	Si. EMe	300	300	2.5A	80W (T_c=25°C)	150	200	300	25	10	500	t_r<1.5μs, t_f<3μs, t_{stg}<2μs									102		
★	〃 1293	三洋	RF	Si. EP	25	25	50	300	125	1	20	15~120	6	1	6	−1					400*	C_{rc} 1.3	$C_c r_{bb}$ 25ps	138		
★	〃 1294	〃																								
★	〃 1295	〃	PA	Si. TMe	1000	350	2 A	40W (T_c=25°C)	150	100	100	3 ~13	5	1 A			t_f<1.3μs							102		
★	〃 1296	〃	SW	Si. T	1300	400	5 A	50W (T_c=25°C)	150	100	100	>4	5	3.5A										102		
★	〃 1297	日電	PA	Si. E	50	25	3.5A	50W (T_c=25°C)	175	1 mA	30	50	10	2 A	10	−700	P_o=26W (f=175MHz, V_{cc}=18V, P_i=10W)				190*	75		149		
★	〃 1298	〃	〃	〃	50	25	5 A	80W (T_c=25°C)	175	2 mA	30	50	10	3 A	10	−1A	P_o=37W (f=175MHz, V_{cc}=18V, P_i=10W)				130*	110		149		
	〃 1299	富士通	SW	Si. TMe	300	200	30A	200W (T_c=25°C)	175	50	150	40	5	10A	5	−2A	t_{on}<2.5μs, t_f<2.5μs t_{stg}<4μs				25*			266		
	〃 1300	〃	〃	〃	500	400	30A	200W (T_c=25°C)	175	50	150	25	5	15A	5	−2A	t_{on}<4μs, t_f<2.5μs t_{stg}<4μs				20*			266		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC1301	富士通	SW	Si.TMe	250	200	30 A	200 W (Tc=25℃)	175	200	150	40	5	10 A	5	−2A	t_{on}<2.5μs, t_f<2.5μs t_{stg}<4 μs				25 *			266	
	〃 1302	〃	〃	〃	400	400	30 A	200 W (Tc=25℃)	175	200	150	25	5	15 A	5	−2A	t_{on}<4μs, t_f<2.5μs t_{stg}<4μs				20 *			266	
★	〃 1303	松下	PA	Si.EP	40	20	300	600	175	1	20	70	13.5	100	10	−30	P_o=0.6W (f=175MHz, V_{cc}=15V, P_i=0.05W)				700 *	6.5	15	84B	
★	〃 1304	日立	〃	Si.T	300	300	500	20W (Tc=25℃)	150	I_{CBX} 100	300	60	10	100	10	−50					7 *	16	20 *	153	
★	〃 1305	日電																							
★	〃 1306	〃	PA	Si.E	65	65R	3 A	12W (Tc=25℃)	150	10	40	80	10	500	10	−150	P_o=5.5W (f=50MHz, V_{cc}=12V, P_i=0.5W)				300 *	20		268	
★	〃 1307	〃	〃	〃	70	70R	8 A	25W (Tc=25℃)	150	20	40	20~150	10	2 A	10	−500	P_o=15W (f=50MHz, V_{cc}=12V, P_i=3 W)				150 *	80		268	
★	〃 1308	三洋	SW	Si.TMe	1500	400	7 A	50W (Tc=25℃)	150	100	100	>3	5	4 A			t_f<1.4μs							102	水平偏向用
★	〃 1309	三菱	SW	Si.EMe	1200	500	5 A	80W (Tc=25℃)	150	1mA	1200	20	10	5 A			t_r<1.5μs, t_f<3μs t_{stg}<2μs							102	
	〃 1310	〃	RF. AF. LN SW	Si.EP	50	50	200	300	125	0.1	25	250	6	1	6	−1		8500	0.6	40	200 *	2.5	$C_c r_{bb'}$ 200ps	175	2SA1299 とコンプリ
★	〃 1311	〃	RF. AF. SW	〃	30	25	100	200	125	0.1	25	250	6	1	6	−1		8500	0.6	40	150 *	2.5	$C_c r_{bb'}$ 200ps	175	
★	〃 1312	〃	RF. AF. LN	〃	35	35	100	200	125	0.1	25	500	6	1	6	−1		19k	1.3	22	150 *	2.5	$C_c r_{bb'}$ 230ps	138B	
★	〃 1313	〃	〃	〃	50	50	100	200	125	0.1	50	350	6	1	6	−1		19k	1.3	22	150 *	2.5	$C_c r_{bb'}$ 230ps	138B	
★	〃 1314	〃	PA	〃	40	18	5 A	45W (Tc=25℃)	175	2mA	15	30	10	200			P_o=34W (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=9W)							127	
★	〃 1315	〃	〃	〃	35	18	500	4 W (Tc=25℃)	175	50	15	50	10	100			P_o=0.5W (f=150MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=0.2W)							84B	
★	〃 1316	ソニー	PA. SW	Si.TMe	750	750	1 A	23W (Tc=25℃)	120	200	50	8	3	2 A	10	−200					8.5 *	120	$C_c r_{bb'}$ 410ps	100	
	〃 1317	松下	PA	Si.EP	30	25	500	625	150	0.1	20	160	10	150	10	−50					200 *	6	3.5 *	138	2SA719 とコンプリ
	〃 1318	〃	〃	〃	60	50	500	625	150	0.1	20	160	10	150	10	−50					200 *	6	3.5 *	138	2SA720 とコンプリ ○
★	〃 1319	日電	RF	Si.P	40	30	25	250	125	0.1	20	90	10	3	10	−3					600 *	1.2	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138	フォワード AGC
★	〃 1320	〃	〃	Si.E	50	40	30	250	125	0.1	20	100	10	10	10	−10					850 *	1.4	$C_c r_{bb'}$ 9 ps	138	
	〃 1321	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	30	25	10	100	125	0.1	25	80	6	2	6	−2					900 *	1.3	$C_c r_{bb'}$ <20ps	176	
	〃 1322	富士通	SW	Si.TMe	250	200	15A	100W (Tc=25℃)	175	100	150	50	5	5 A	5	−1A	t_{on}<1μs, t_f<1.5μs t_{stg}<4μs				27 *			102	
★	〃 1323	三菱	PA	Si.EP	30	16	500	5 W (Tc=25℃)	175	50	15	70	15	30			PG=14.2dB (f=220MHz, I_C=30mA, V_{cc}=13.5V)							271	
	〃 1324	〃	〃	〃	35	25	150	800	175	50	25	70	10	30			G_{pe}=10dB (f=770MHz, I_C=30mA, V_{cc}=15V)							85B	
	〃 1325	日電	SW	Si.TMe	1500	600	6 A	80W (Tc=25℃)	150	20	1000	19	15	1 A			t_r<2.5μs, t_f<1μs, t_{stg}<1.5μs							102	○
	〃 1326	松下	PA	Si.EP	55	30	400	5 W (Tc=25℃)	175	I_{CEO} 20	V_{CE} 28	30	5	50	15	−25	P_o>1 W, η>45% (f=400MHz, V_{CC}=28V, P_i=0.1W)				700 *	<3		84B	
★	〃 1327	〃	RF, LN	〃	35	35	50	400	150	0.1	10	540	5	2	5	−2		5500	0.4	25	250 *	2.2	70	138	2SA721 とコンプリ
★	〃 1328	〃	〃	〃	55	55	50	400	150	0.1	10	540	5	2	5	−2		5500	0.4	25	250 *	2.2	70	138	2SA722 とコンプリ
★	〃 1329	日電	RF	Si.E	50	25	8 A	60W (Tc=25℃)	200	2mA	30	100	10	5 A			P_o=32W (f=70MHz, V_{cc}=12V, P_i=8W)							149	
★	〃 1330	〃	RF. AF	〃	50	40	100	400	125	0.1	40	150	6	1	6	−1		4800	4.5	17	250 *	4.5	25 *	44	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC1331	日電	RF. Conv. Mix. Osc	Si. P	20	20	20	150	150	50nA	10	100	5	4	10	−4					750*	C_{re} 0.37	$C_c r_{bb'}$ 10ps	50C		
★	〃 1332	〃																								
★	〃 1333	〃	PA	Si. E	45	25	1 A	10W (T_c=25°C)	175	100	30	20~200	10	300	10	−200	G_{pe} = 5 dB (f=1GHz, V_{cc}=18V, P_i=1W)				1200*	8		184		
★	〃 1334	〃	〃	〃	45	30	1 A	11.6W (T_c=25°C)	200	100	30	15~250	10	300			G_{pe} = 4 dB (f=1GHz, V_{cc}=24V, P_i=2W)							184		
★	〃 1335	日立	LN	Si.EPa	30	30	100	200	125	0.5	18	250~1200	12	2	NF = 3 dB (f=120Hz, I_C=0.1mA)						230*	<3.5		138		
	〃 1336	日電	RF	Si. E	20	15	30	250	200	0.1	10	100	10	10	10	−10	G_{pe}=11dB (f=2GHz)				4500*	NF = 3 dB (f=2GHz)		190		
★	〃 1337	三菱	PA	Si. EP	35	17	2 A	20W (T_c=25°C)	175	200	15	50	10	100			P_o=8.5W (f=485MHz, V_{cc}=13.5V, P_i= 2 W)							126		○
★	〃 1338	〃	〃	〃	35	17	3 A	30W (T_c=25°C)	175	500	15	50	10	100			P_o=16W (f=485MHz, V_{cc}=13.5V, P_i= 6 W)							126		○
★	〃 1339	〃	〃	〃	35	17	5 A	40W (T_c=25°C)	175	1mA	15	50	10	100			P_o=28W (f=485MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=12W)							126		
★	〃 1340	〃	〃	〃	35	25	1 A	5 W (T_c=25°C)	175	100	25	70	10	100			G_{pe}=19dB (f=220MHz, V_{cc}=15V, I_C=100mA)							312		
★	〃 1341	〃																								
	〃 1342	日立	RF. Conv. Mix. Osc	Si. P	30	20	30	100	150	0.5	10	35~200	6	1	6	−1	G_{pr}=17dB (f=100MHz, V_{CE}=6V, I_C=1mA)				320*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 20ps	138		
	〃 1343	〃	PA.SW	Si. T	130	110	10 A	100W (T_c=25°C)	150	1mA	30	30~200	5	1 A	5	−1A					15*	240		102	2SA753 とコンプリ	
	〃 1344	〃	LN	Si. E	30	30	100	200	150	0.5	18	250~1200	12	2	NF< 1 dB (f=1kHz, I_C=0.1mA)						230*	<3.5	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138		
	〃 1345	〃	〃	〃	55	50	100	200	150	0.5	18	250~1200	12	2	NF< 1 dB (f=1kHz, I_C=0.1mA)						230*	<3.5	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138		
★	〃 1346	松下	PA	Si. EP	30	25	500	600	125	0.1	20	160	10	150	10	−50					200*	6	3.5*	171	2SA730 とコンプリ	
★	〃 1347	〃	〃	〃	60	50	500	600	125	0.1	20	160	10	150	10	−50					200*	6	3.5*	171	2SA731 とコンプリ	
★	〃 1348	ソニー	SW	Si. TMe	1000	1000S	4 A	125W (T_c=25°C)	120	2mA	800	8	3	2 A	10	−2A					5*	175	$C_c r_{bb'}$ 200ps	102	水平偏向用	
	〃 1349	富士通	〃	Si.EP	20	15	200	200	175	0.4	15	60	1	10			t_r= 4 ns, t_f= 9 ns t_{stg}= 6 ns							46C		
★	〃 1350	〃																								
★	〃 1351	〃																								
★	〃 1352	〃																								
★	〃 1353	〃																								
★	〃 1354	松下	PA	Si. EP	55	35	5 A	60W (T_c=25°C)	175	1mA	20	50	13.5	1 A			P_o=37W (f=175MHz, V_{CE}=24V, P_i=8W)							143		
★	〃 1355	富士通	〃	〃	40	35	700	7 W (T_c=25°C)	175	100	20	80	5	200	12	−200	P_o= 2 W (f=700MHz, V_{cc}=18V, P_i=0.5W)				1800*	5		159		
★	〃 1356	〃	〃	〃	40	35	1 A	12W (T_c=25°C)	175	200	20	80	5	500	12	−300	P_o= 6 W (f=700MHz, V_{cc}=18V, P_i= 2 W)				1800*	8		159		
★	〃 1357	日電																								
	〃 1358	〃	SW	Si. TMe	1400	500	4.5A	50W (T_c=25°C)	150	20	1000	19	15	500			t_f<1μs, t_{stg}<10μs							102		○
	〃 1359	松下	RF	Si. EP	30	20	30	400	150	0.1	10	100	10	1	10	−1					250*	C_{re} 0.9pF	22	138	2SA838 とコンプリ	
	〃 1360	〃	〃	〃	50	45	50	1 W	150	0.1	20	50	10	10	10	−10					500*	1.5	20	294		○

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC1361	ソニー	RF.LN	Si.PaMe	25	25	200	320	100	0.2	25	200	3	1	6	−0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350ps	138		
★	〃 1362	〃	〃	〃	50	50	200	320	100	0.2	25	200	3	1	6	−0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350ps	138		
★	〃 1363	〃	RF	〃	25	25	200	320	100	0.2	25	200	3	1	6	−2					140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350ps	138		
★	〃 1364	〃	〃	Si.PaMe	50	50	200	320	120	0.2	25	200	3	1	6	−2	h_{fe} = 3 dB (f = 100MHz)				140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 300ps	138		
	〃 1365	日電	〃	Si.E	45	25	300	800	200	0.5	20	80	15	50	15	−70	G_p = 17dB (f = 200MHz)				1700*	NF = 3 dB (f = 200MHz)		84B		
	〃 1366	〃	〃	〃	45	25	300	800	200	0.5	20	80	10	50	15	−50	G_p = 18dB (f = 200MHz)				2000*	NF = 3 dB (f = 200MHz)		84B		
★	〃 1367	日立	PA	Si.TMe	1000	600	1 A	50W (T_c=25℃)	125	10	500	45	10	200	15	−200					6*	60	25	102		○
	〃 1368	〃	〃	Si.EPa	25	25	2.5A	8W (T_c=25℃)	150	20	25	60~320	2	500	2	−200					180*	30		160	2SA738 とコンプリ	
★	〃 1369	新電元																								
★	〃 1370	〃																								
★	〃 1371	〃																								
★	〃 1372	富士通	RF.SW	Si.EP	30	20	200	200	125	0.5	10	100	1	10	6	−2					250*	4	80*	138		
	〃 1373	日立	SW	〃	25	10	100	300	175	1	20	90	4	35			t_{on}<100ns, t_{off}<325ns t_{stg}<290ns							49C		
	〃 1374	〃	〃	〃	25	13	100	300	175	0.25	20	>30	1	70			t_r< 7 ns, t_f< 6 ns t_{stg}<12 ns							49C		
	〃 1375	〃	〃	〃	25	10	100	300	175	0.05	5	>54	0.4	50			t_{on}<45ns, t_{off}<60ns							49C		
	〃 1376	〃	〃	〃	40	15	500	300	175	I_{CES} 0.5	20	65	1	150	10	−30	t_{on}<25ns, t_{off}<25ns				590*	2.7		49C		
★	〃 1377	東芝	PA	Si.E	90	45	6 A	20W (T_c=25℃)	150	10	60	>20	5	1 A	5	−200	P_o > 8 W (f=27MHz, V_{cc}=12V, P_i=1W)				100*	60		268		
★	〃 1378	〃	〃	〃	40	18	4 A	35W (T_c=25℃)	175	100	15	>10	5	10A	10	−200	P_o=25W (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=6W)				150*	65	2*	135		
★	〃 1379	〃	〃	〃	40	18	7 A	70W (T_c=25℃)	175	100	15	>10	5	1 A	10	−200	P_o=40W (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=12W)				150*	130	1*	193		
	〃 1380	〃	RF	〃	55	50	100	200	150	0.1	18	200~700	6	2	6	−1					80*	6		49C		○
★	〃 1381	〃	RF.PA	〃	100	100	1 A	800	150	1	30	70~240	2	150	2	−150					50*	20	10	342		
★	〃 1382	〃	〃	〃	80	80	750	800	150	0.1	30	70~240	2	150	2	−150					100*	15		342	2SA682 とコンプリ	
	〃 1383	松下	PA	Si.EP	30	25	1 A	1 W	150	0.1	20	160	10	500	10	−50					200*	11	3.5*	294	2SA683 とコンプリ	
	〃 1384	〃	〃	〃	60	50	1 A	1 W	150	0.1	20	160	10	500	10	−50					200*	11	3.5*	294	2SA684 とコンプリ	
	〃 1385	日立	SW	〃	60	30	500	800	175	0.5	30	>35	1.1	300			t_{on}<40ns, t_{off}<60ns							123		
	〃 1386	〃	〃	〃	70	52	1 A	800	175	100	60	>30	1	60		30	t_{on}<30ns, t_{off}<55ns							123		
	〃 1387	富士通	RF	〃	25	20	150	600	150	0.5	20	100	10	40	10	−40					1600*	2.5	40*	84B		
	〃 1388	〃	SW	〃	100	80	1 A	800	200	0.5	70	>15	3	500			t_{on}<50ns, t_{off}<110ns t_{stg}<80ns							84C		
	〃 1389																									
	〃 1390	日立	RF.LN	Si.E	20	20	50	200	125	1	18	500	12	2	12	−2	NF=0.5dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				230*	2	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	r_{bb} h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1391	日立	PA	Si. T	300	300X	100	6.5W (Tc=25°C)	150	100	300	60	10	50	50	−20					25*	5	20*	153		
★	〃 1392	日電																								
	〃 1393	〃	RF. LN	Si. E	30	30	20	250	125	0.1	20	100	10	2	10	−3		NF=2 dB (f=200MHz)			700*	Crr 0.35	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138C		
	〃 1394	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	30	30	20	250	125	0.1	20	100	10	2	10	−3					700*	Crr 0.35	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138C		
★	〃 1395	〃	〃	Si. EP	30	15	20	250	125	0.1	12	100	10	5	10	−5					1100*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138		
★	〃 1396	〃	〃	〃	30	15	20	250	125	0.1	12	100	10	5	10	−5					1100*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138		
★	〃 1397	〃																								
	〃 1398	松下	RF. PA	Si. EP	70	50	2 A	15W (Tc=25°C)	150	1	40	130	5	1 A	5	−500					150*	50	3*	268	2SA748 とコンプリ	○
★	〃 1399	日電	AF	Si. E	100	80	50	250	125	0.05	100	600	3	0.5	6	−1					100*	2.7		138		
★	〃 1400	〃	LN	Si.EPa	100	80	50	250	125	0.05	100	500	3	0.5	6	−1					100*	2.7	50*	138		
	〃 1401	富士通	SW	Si.TMe	400	350	30 A	200W (Tc=25°C)	175	200	150	25	5	15 A	5	−2A	t_{on}<4μs, t_f<2.5μs t_{stg}<4μs				20*			266		
★	〃 1402	サンケン	PA	Si.TMe	140	80	8 A	70W (Tc=25°C)	150	1mA	140	60	4	3 A	12	−500					10*	130	7*	102	2SA744 とコンプリ	
★	〃 1403	〃	〃	〃	160	100	8 A	70W (Tc=25°C)	150	1mA	160	60	4	3 A	12	−500					10*	130	7*	102	2SA745 とコンプリ	○
	〃 1404	松下	〃	Si.EP	36	18	3.5A	50W (Tc=25°C)	200	25mA	36	30	5	1 A	5	−1A	P_o=18W (f=470MHz, V_{cc}=12.5V, P_i=6.8W)				1000*	55		229		
★	〃 1405	〃	〃	〃	36	18	750	10W (Tc=25°C)	175	50	20	40	10	100	10	−100	P_o=3.5W, G_{pe}=10dB (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=0.35W)				350*	13		227		
★	〃 1406	〃	〃	〃	30	25	1 A	1 W	135	0.1	20	160	10	500	10	−50					200*	11	3.5*	173	2SA751 とコンプリ	
★	〃 1407	〃	〃	〃	60	50	1 A	1 W	135	0.1	20	160	10	500	10	−50					200*	11	3.5*	173	2SA752 とコンプリ	
★	〃 1408	三洋																								
★	〃 1409	日立	PA	Si.TMe	200	120	2 A	12.5W (Tc=25°C)	150	1	30	100	10	50	10	−50					20*	95	20	267		○
★	〃 1410	〃	〃	〃	200	120	2 A	12.5W (Tc=25°C)	150	1	30	100	10	50	10	−50					20*	95	20	268		○
	〃 1411	富士通	SW	Si. EP (反方向)	6	4	50	200	150	0.1	5	100					t_r<300ns, t_f<500ns t_{stg}<600ns					6		49C		
	〃 1412	〃	RF	Si. EP	45		150	600	150	0.5	20	70	10	40	10	−40					1500*	2.5	40	84B		
	〃 1413	日立	SW	Si. T	1200	500	5 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CBX} 1mA	1200				15	−200	t_f<2.3μs				4*	175		102	水平偏向用	○
★	〃 1414	富士通	PA	Si. EP	40	35	2 A	20W (Tc=25°C)	175	400	20	80	5	1 A	12	−500	P_o=10W (f=700MHz, V_{cc}=18V, P_i=4W)				1500*	13		159		
★	〃 1415	〃	〃	〃	40	35	3 A	25W (Tc=25°C)	175	600	20	80	5	2 A	12	−500	P_o=16W (f=700MHz, V_{cc}=18V, P_i=7.5W)				1200*	18		159		
★	〃 1416	東芝	RF	〃	55	50	50	200	150	0.1	30	350	6	2	6	−1	NF=2 dB (f=100Hz, V_{CE}=6V, I_E=−0.1mA)				100*	3	45	195		○
	〃 1417	日立	RF. Conv. Mix. Osc	Si. P	20	15	30	100	125	1	10	100	6	1	6	−1					300*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 24ps	37		
★	〃 1418	〃	PA	Si.T	50		2 A	20W (Tc=25°C)	150	100	30	35~320	4	1 A	4	−500					5*			267	2SA754 とコンプリ	
★	〃 1419	〃	〃	〃	50	50	2 A	20W (Tc=25°C)	150	100	20	35~320	4	1 A	4	−500					5*			268	2SA755 とコンプリ	
★	〃 1420	富士通	RF	Si. EP	15	10	70	300	150	0.5	10	80	6	40	6	−40					6000*	1	25*	199		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1421	富士通	RF	Si. EP	15	10	30	250	150	0.5	10	80	6	10	6	−10	NF=6 dB (f=2GHz, I_C=4mA)				5500*	0.7	25*	199	
	〃 1422	〃	〃	〃	15	10	40	250	150	0.5	10	80	6	20	6	−20	〃				5500*	0.8	25*	199	
★	〃 1423	〃	〃	〃	15	10	30	250	150	0.5	10	80	6	15	6	−15	NF=3.5dB (f=2GHz, I_C=4mA)				7000*	0.7	25*	199	
	〃 1424	日電	〃	Si. E	30	14	50	250	200	0.1	15	80	10	10	10	−10	G_p=15dB (f=500MHz)				2000*	1.1		50C	
★	〃 1425	〃	PA	〃	45	25	1 A	11.6W (T_c=25°C)	200	100	30	15~250	10	300			G_{pe}= 5 dB (f=1GHz, V_{cc}=18V, P_i=1W)							184	
	〃 1426	〃	RF	〃	35	18	200	3.5W (T_c=25°C)	200	0.1	20	100	10	50	10	−50					2700*	1		85B	
	〃 1427	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	30	25	10	100	125	0.1	25	120	6	2	6	−2					1000*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 3 ps	176	
	〃 1428	〃	〃	〃	50	25	50	150	125	0.1	15	110	3	0.5	6	−1					250*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 25 ps	176	
★	〃 1429	ソニー	PA	Si. E PaMe	16	12	2 A	950	120	0.1	16	200	2	100	2	−10					80*	26	$C_c r_{bb'}$ 300 ps	174	
★	〃 1430	〃	RF. PA	Si. EMe	110	110	1.5A	500	150	100	50	100	2	400	2	−200					50*	50	$C_c r_{bb'}$ 25 ps	181	
★	〃 1431	〃	〃	〃	110	110	2A	1.5W	150	10	50	100	2	400	2	−100					80*	25	$C_c r_{bb'}$ 25 ps	99	
★	〃 1432	新日無	SW	Si. EP	30	15	300	300	125	1	20	40,000	6	100			t_{on}<600ns, t_{off}<1.2μs t_{stg}<600ns							138	2SA796 とコンプリ
★	〃 1433	東芝	PA. SW	Si. TMe	600	400	5 A	50W (T_c=25°C)	150	100	500	20~300	5	1 A	50		t_{on}< 2 μs, t_f<1.5μs t_{stg}<10μs					100		102	
★	〃 1434	〃	〃	〃	600	400	15 A	150W (T_c=25°C)	150	500	500	30~300	5	3 A	50		t_{on}< 2 μs, t_f<2.5μs t_{stg}<15μs					200		102	
★	〃 1435	〃	〃	〃	600	400	40 A	300W (T_c=25°C)	150	1mA	500	30~300	5	10 A	50		t_{on}<11μs, t_f<1.5μs t_{stg}<10μs					600		196	
★	〃 1436	サンケン	SW	Si.TMe	230	230	15A	100W (T_c=25°C)	150	1mA	230	20	4	5 A	12	−500	t_r<1.5μs t_f<1μs t_{stg}<4μs, t_d<0.5μs				10*			102	
★	〃 1437	〃	〃	〃	230	230	50A	200W (T_c=25°C)	150	1mA	230	20	4	10A	12	−500	t_r<1.5μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs				10*			230	
	〃 1438	富士通	RF	Si. EP	150	130	50	500	150	1	140	150	5	10	5	−10					130*	3		138	
	〃 1439	〃	〃	〃	150	150	50	500	150	1	140	150	5	10	5	−10					130*	3		138	
★	〃 1440	サンケン	SW	Si.TMe	150	150	15A	100W (T_c=25°C)	150	1mA	150	20	4	5 A	12	−500	t_r<1.5μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs, t_d<0.5μs				10*			102	
★	〃 1441	〃	〃	〃	200	200	15A	100W (T_c=25°C)	150	1mA	200	20	4	5 A	12	−500	t_r<1.5μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs, t_d<0.5μs				10*			102	
★	〃 1442	〃	〃	〃	150	150	50A	200W (T_c=25°C)	150	1mA	150	20	4	10A	12	−500	t_r<1.5μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs				10*			230	
★	〃 1443	〃	〃	〃	200	200	50A	200W (T_c=25°C)	150	1mA	200	20	4	10A	12	−500	t_r<1.5μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs				10*			230	
★	〃 1444	〃	PA	〃	80	60	6 A	40W (T_c=25°C)	150	1mA	80	80	4	1 A	10	−500					10*	85	12*	99	2SA764 とコンプリ
★	〃 1445	〃	〃	〃	100	80	6 A	40W (T_c=25°C)	150	1mA	100	80	4	1 A	10	−500					10*	85	12*	99	2SA765 とコンプリ
★	〃 1446	松下	〃	Si.TP	300	300	100	10W (T_c=70°C)	150	100	300	70	10	50	30	−20					55*	8	10	268	
★	〃 1447	東芝	RF. PA	Si. T	300	300	150	20W (T_c=25°C)	150	1	240	40~170	10	50	50	−20					80*	7	30	268	
★	〃 1448	〃	〃	Si. TMe	150	150	1.5A	25W (T_c=25°C)	150	20	100	75	10	500	10	−500					5*	50	25	268	2SA740 とコンプリ
	〃 1449	日電	PA	Si.E	40	35	2 A	10W (T_c=25°C)	150	0.5	35	90	2	300	5	−100					55*	20	40*	225	
★	〃 1450	松下	〃	Si. Me	150	150R	400	20W (T_c=80°C)	150	30	60	70	5	100	10	100					15*	50	25	99	2SA766 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1451	富士通	RF	Si.EP	150	120	50	700	175	1	140	150	5	10	5	−10	t_{on}<1μs, t_{off}<10μs t_{stg}<9.5μs				130*	2	70*	248	
★	〃 1452	〃	〃	〃	150	150	50	700	175	1	140	150	5	10	5	−10	t_{on}<1μs, t_{off}<10μs t_{stg}<9.5μs				130*	2	70*	248	
★	〃 1453	東芝	〃	〃	55	50	100	200	150	0.1	30	120	1	10	10	−1					150*	5	20	195	
★	〃 1454	サンケン	PA	Si.TMe	300	250	4 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	>20	5	1 A	12	−100					10*			102	
	〃 1455	三菱																							
★	〃 1456	日電	PA	Si.TP	300	300	200	15W (Tc=25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	−10					80*	3.8	30	99	
	〃 1457	〃	RF	Si.E	35	18	150	800	200	0.1	20	100	10	50	10	−50	NF<3.2dB (f=200MHz, V_{CE}=10V, I_C=20mA)				2700*	C_{rc} 1	45*	85B	
	〃 1458	〃	〃	〃	20	12	50	300	200	0.1	10	100	5	30	5	−15	$\|S_{21e}\|^2$ = 9 dB (f=1GHz)				3000*	C_{rc} 0.9	30*	130	
★	〃 1459	富士通	〃	Si.EP	15	10	70	300	175	0.5	10	80	6	40	6	−40					5000*	1	25*	199	
★	〃 1460	〃	〃	〃	15	10	30	250	175	0.5	10	80	6	10	6	−10	NF=4.5dB (f=2GHz, V_{CE}=6V, I_C=4mA)				4500*	0.7	25*	199	
★	〃 1461	〃	〃	〃	15	10	40	250	175	0.5	10	80	6	20	6	−20	〃				4500*	0.8	25*	199	
	〃 1462	〃	〃	〃	15	10	30	250	175	0.5	10	80	6	15	6	−15	NF=3.5dB (f=2GHz, V_{CE}=6V, I_C=4mA)				6500*	0.7	25*	199	
	〃 1463	〃	SW	Si.T	450	400	4 A	75W (Tc=25°C)	175	10	150	18	5	1 A	6	−300	t_r<5μs t_f<3μs t_{stg}<5μs				25*	125	5*	102	
	〃 1464	〃	PA	Si.EP	50	25	500	4 W (Tc=25°C)	175	250	20	80	5	200	12	−100	P_o=1.2W (f=175MHz, V_{cc}=12V, P_i=50mW)				1300*	3.5		84C	
	〃 1465	〃	〃	〃	50	25	500	7 W (Tc=25°C)	175	250	20	80	5	200	12	−100	P_o=1.8W, η=55% (f=0.7GHz, V_{cc}=24V, P_i=0.3W)				1600*	4.5		231	
	〃 1466	新電元	SW	Si.DB	450	360	3 A	30W (Tc=25°C)	150	1mA	450	16	5	1.5A	10	1 A	t_{on}<2μs, t_f<2μs t_{stg}<4μs				10*	60		204	T3M36
	〃 1467	〃	〃	〃	500	400	3 A	30W (Tc=25°C)	150	1mA	500	12	5	1.5A	10	1 A	〃				10*	60		204	T3M40
	〃 1468	〃	〃	〃	450	360	10 A	100W (Tc=25°C)	150	10mA	450	16	5	5 A	10	1 A	〃				10*	300		102	T10M36
	〃 1469	〃	〃	〃	500	400	10 A	100W (Tc=25°C)	150	10mA	500	12	5	5 A	10	2 A	〃				10*	300		102	T10M40 ○
	〃 1470	〃	〃	〃	450	360	30 A	200W (Tc=25°C)	150	10mA	450	16	5	10 A	10	2 A	〃				10*	700		266	T30M36
	〃 1471	〃	〃	〃	500	400	30 A	200W (Tc=25°C)	150	10mA	500	12	5	10 A	10	2 A	〃				10*	700		266	T30M40 ○
	〃 1472	日立	RF	Si.EP	40	30	300	500	150	0.1	30	2000~100000	5	10	5	−10	t_{on}=60ns, t_{off}=800ns t_{stg}=350ns				>50*	<10	220	138	ダーリントン
	〃 1473	松下	PA	Si.TP	250	200	70	600	125	2	12	120	10	5	10	−10					80*	5	$C_c r_{bb'}$ 60ps	138	2SA1018とコンプリ ○
★	〃 1474	ソニー	RF.PA	Si.PaMe	16	16	2 A	750	120	0.2	16	300	2	100	2	−10					60*	30	$C_c r_{bb'}$ 600ps	294	2SA772とコンプリ
★	〃 1475	〃	〃	〃	100	50	1 A	750	120	0.2	25	300	2	100	2	−10					80*	16	$C_c r_{bb'}$ 300ps	294	2SA773とコンプリ
★	〃 1476	東芝	PA	Si.EP	38	18	5 A	40W (Tc=25°C)	175	1mA	15	50	5	1 A			P_o=28W (f=470MHz, V_{cc}=12.6V, P_i=12W)							135	
★	〃 1477	サンケン	SW	Si.T	230	230	9 A	80W (Tc=25°C)	150	1mA	230	20	4	5 A			t_r<1.5μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs							102	
★	〃 1478	松下	RF.LN	Si.EP	35	35	50	150	175	0.1	10	540	5	2	5	−2		5500	0.4	25	150*	2.2	70	243	○
	〃 1479	富士通	PA	〃	36	33R	500	3 W (Tc=25°C)	175	100	12	50	2	200	12	−100	P_o=1.2W (f=175MHz, V_{cc}=12.5V, P_i=50mW)				1000*	4		84C	
	〃 1480	〃	〃	〃	36	16	500	7 W (Tc=25°C)	175	100	12	50	2	500	12	−100	P_o=2.4W, η=60% (f=470MHz, V_{cc}=12.5V, P_i=0.3W)				1200*	5		246	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE} V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1481	富士通	PA	Si. EP	36	16	1 A	12W (Tc=25°C)	175	200	12	50	2	1A	12	−200	P_o=5 W, η=60% (f=470MHz, Vcc=12.5V, P_i=1W)				1000*	10		246	
	〃 1482	〃	〃	〃	36	16	2 A	20W (Tc=25°C)	175	500	12	50	2	2A	12	−500	P_o=8.5W, η=70% (f=470MHz, Vcc=12.5V, P_i=2W)				800*	18		246	
	〃 1483	〃	LN	〃	20	10	40	300	150	0.1	10	100	6	10	6	−10	NF=2 dB (f=100MHz, V_{CE}=6V, I_C=5mA)				3000*	0.9	25*	214	
★	〃 1484	〃	RF	〃	45	30	300	5 W (Tc=25°C)	150	1	25	80	15	65	15	−65					2000*	2.8	25*	146A	
	〃 1485	〃	SW	Si. T	250	250	125	350	175	1	30	90	4	10			t_r<2μs, t_f<2.5μs t_{stg}<6μs z							49C	
★	〃 1486	モトローラ	PA	Si. EP	36	16	400	5 W (Tc=25°C)	200	1mA	15	80	5	100			G_{pe}=10dB, η>60% (f=470MHz, Vcc=12.5V, Ic=0.24A)					11		216	2N5944
★	〃 1487	〃	〃	〃	36	16	800	15W (Tc=25°C)	200	1mA	15	80	5	200			G_{pe}=9 dB, η>60% (f=470MHz, Vcc=12.5V, Ic=0.5A)					18		216	2N5945
★	〃 1488	〃	〃	〃	36	16	2 A	37.5W (Tc=25°C)	200	2mA	15	80	5	500			G_{pe}=7 dB, η>60% (f=470MHz, Vcc=12.5V, Ic=1.3A)					38		216	2N5946
★	〃 1489	〃	〃	〃	36	18	6 A	60W (Tc=25°C)	200	2.5mA	15	80	5	1 A			G_{pe}=4.3dB, η>65% (f=470MHz, Vcc=12.5V, P_i=10W)					55		217	2N6136
★	〃 1490	〃	〃	〃	36	18	1 A	12W (Tc=25°C)	200	250	15	80	5	250			G_{pe}=13dB, η>50% (f=175MHz, Vcc=12.5V, P_i=0.25W)					15		217	2N6080
★	〃 1491	〃	〃	〃	36	18	2.5A	31W (Tc=25°C)	200	500	15	50	5	500			G_{pe}=7 dB, η>60% (f=175MHz, Vcc=12.5V, P_i=3.6W)					70		217	2N6081
★	〃 1492	〃	〃	〃	36	18	4 A	65W (Tc=25°C)	200	1mA	15	50	5	1 A			G_{pe}=7 dB, η>65% (f=175MHz, Vcc=12.5V, P_i=6 W)					110		217	2N6082
★	〃 1493	〃	〃	〃	36	18	4 A	65W (Tc=25°C)	200	1mA	15	50	5	1 A			G_{pe}=6.5dB, η>65% (f=175MHz, Vcc=12.5V, P_i=8.1W)					110		217	2N6083
★	〃 1494	〃	〃	〃	36	18	6 A	80W (Tc=25°C)	200	2.5mA	15	40	5	1 A			G_{pe}=5 dB, η>70% (f=175MHz, Vcc=12.5V, P_i=14.3W)					170		217	2N6084
★	〃 1495	〃	〃	〃	36	16	400	2 W (Tc=25°C)	200	500	15	80	5	50			G_{pe}=9 dB, η>60% (f=470MHz, Vcc=12.5V, P_i=0.1W)					6		218	2N6256
★	〃 1496																								
★	〃 1497																								
★	〃 1498	モトローラ	PA	Si. EP	36	18	2.5A	45W (Tc=25°C)	200	1mA	15	80	5	1 A			G_{pe}=7 dB, η>60% (f=470MHz, Vcc=12.5V, P_i=3.75W)					65		219	
★	〃 1499	〃	〃	〃	36	16	6 A	115W (Tc=25°C)	200	20mA	15	60	5	4 A			G_{pe}=6 dB, η>55% (f=470MHz, Vcc=12.5V, P_i=7.6W)					85		219	
★	〃 1500	〃	〃	〃	36	16	8 A	115W (Tc=25°C)	200	20mA	15	60	5	4 A			G_{pe}=4.9dB, η>55% (f=470MHz, Vcc=12.5V, P_i=13W)					85		219	
	〃 1501	松下	PA	Si. TP	300	300R	100	10W (Tc=70°C)	150	100	300	70	10	50	30	−20					55*	8	10	236	
★	〃 1502	東芝																							
★	〃 1503	〃	PA	Si. EP	50	25	3 A	30W (Tc=25°C)	175	500	20	50	5	1 A			P_o=13W (f=260MHz, Vcc=20V, P_i=1W)							135	
★	〃 1504	サンケン	SW	Si.TMe	400	300	2 A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	400	60	4	1 A	12	−100	t_r<2μs, t_f<6μs t_{stg}<9μs				10*			99	
	〃 1505	日電	PA	Si. T	300	300	200	15 (Tc=25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	−10					80*	<4.5	30	268	
	〃 1506	〃	〃	〃	300	300	200	15W (Tc=25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	−10					80*	<4.5	30	267	
	〃 1507	〃	〃	〃	300	300	200	15W (Tc=25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	−10					80*	<4.5	30	250	
★	〃 1508	三菱																							
	〃 1509	松下	PA	Si. EP	80	80	500	1 W	150	0.1	20	160	10	150	10	−50					120*	11		294	2SA777 とコンプリ
★	〃 1510	三菱	〃	〃	47	47R	1 A	10W (Tc=25°C)	175	200	30	50	25	100			P_o=4.5W (f=770MHz, Vcc=25V, P_i=1.2W)						2k*	209	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC1511	日電	PA	Si. E	50	25	3 A	50W (Tc=25℃)	175	2mA	30	60	10	700			P_o=25W (f=275MHz, Vcc=18V, Pi=6W)							233	
★	〃 1512	〃	〃	〃	50	25	5 A	65.2W (Tc=25℃)	175	3mA	30	60	10	1 A			P_o=37W (f=275MHz, Vcc=18V, Pi=10W)							233	
★	〃 1513	日立	RF	Si. Pa	40	25	300	800	175			35~250	15	30	15	−30	G_{pe}>15dB, NF=3.5dB (f=200MHz, Ic=30mA)				1800*	Cre< 3pF		85C	
	〃 1514	〃	RF.PA	Si.T	300	300	100	1.25W	150	I_{CEO} 1	V_{CE} 250	30~200	20	20	20	−20					80*	<4		234	
	〃 1515	〃	SW	Si. T	200	150	50	200	125	0.1	20	30~300	6	10	6	−10					>60*	<10	$C_c r_{bb'}$ 40ps	138	
	〃 1516	〃	PA.SW	Si. E	35	35	1.5A	10W (Tc=25℃)	150	20	30	60~200	2	500	2	−200	t_{on}≒140ns, t_{off}=650ns t_{stg}=600ns				110*	35		234	2SA779 とコンプリ
	〃 1517	〃	〃	Si. T	50	50	1 A	10W (Tc=25℃)	150	5	30	160	4	50	4	−50					10*	30	50*	234	2SA780 とコンプリ
	〃 1518	松下	PA	Si. EP	25	20	1 A	750	135	0.1	25	160	2	500	10	−50					150*	12	3.5k*	294	
★	〃 1519	日電	〃	Si. TP	250	250	200	10W (Tc=25℃)	150	0.1	200	90	10	10	10	−10					80*	3.5	30	289	
★	〃 1520	〃	〃	〃	250	250	200	10W (Tc=25℃)	150	0.1	150	80	10	10	30	−10					80*	<4.5	30	290	
★	〃 1521	〃	〃	〃	250	250	200	10W (Tc=25℃)	150	0.1	150	80	10	10	30	−10					80*	<4.5	30	291	
★	〃 1522	〃	〃	〃	250	250	200	10W (Tc=25℃)	150	0.1	200	90	10	10	10	−10					80*	3.5	30	292	
★	〃 1523	日立	RF.PA	Si.Pa	40	25	300	3.5W (Tc=25℃)	175	10	15	35~250	15	50			G_{pe}>17dB, NF<5dB (f=200MHz, VCE=15V)				2000*	Cre 3		269	
	〃 1524	富士通	PA	Si. EP	50	30	1 A	12W (Tc=25℃)	175	200	20	50	5	500	12	−250	P_o=8W, η=55% (f=700MHz, Vcc=24V, Pi=2W)				800*	8		246	
	〃 1525	〃	〃	〃	50	30	2 A	20W (Tc=25℃)	175	400	20	50	5	1 A	12	−500	P_o=13W, η=55% (f=700MHz, Vcc=24V, Pi=4W)				800*	13		246	
	〃 1526	〃	〃	〃	50	30	3 A	25W (Tc=25℃)	175	600	20	50	5	2 A	12	−500	P_o=22W, η=55% (f=700MHz, Vcc=24V, Pi=7.5W)				1000*	18		246	
★	〃 1527	〃																							
★	〃 1528	三菱	PA	Si. EP	40	18	2.5A	25W (Tc=25℃)	175	500	25	40	10	100			P_o=16W (f=175MHz, Vcc=13.5V, Pi=3.5W)							271	
	〃 1529	〃	RF	〃	30	25	20	120	150	0.1	12	60	10	5			G_{pe}=13dB (f=770MHz, Vcc=10V, Ic=5mA)							50C	
	〃 1530	〃	PA	〃	50	50R	350	5 W (Tc=25℃)	150	100	30	50	10	100			P_o=1.5W (f=1GHz, Vcc=28V, Pi=0.25W							312	
★	〃 1531	東芝																							
★	〃 1532	〃	SW	Si.TMe	300	200	30A	200W (Tc=25℃)	150	500	300	20~100	5	20A										196	
★	〃 1533	富士通	PA	Si. EP	45	23	500	7 W (Tc=25℃)	175	100	20	50	5	200	12	−200	P_o=2.2W (f=700MHz, Vcc=18V, Pi=0.5W)				1.8GHz*	5		246	
	〃 1534	〃	〃	〃	45	23	1 A	12W (Tc=25℃)	175	200	20	50	5	500	12	−300	P_o=7W (f=700MHz, Vcc=18V, Pi=2W)				1.6GHz*	8		246	
	〃 1535	〃	〃	〃	45	23	2 A	25W (Tc=25℃)	175	400	20	50	5	1 A	12	−500	P_o=12W (f=700MHz, Vcc=18V, Pi=4W)				1.2GHz*	13		246	
	〃 1536	〃	〃	〃	45	23	4 A	40W (Tc=25℃)	175	800	20	50	5	3 A	12	−700	P_o=24W (f=700MHz, Vcc=18V, Pi=10W)				800*	23		246	
★	〃 1537	ローム	RF. ConV. Mix Osc.AF.PA.SW	〃	50	40	30	150	125	1	30	330	3	0.5	6	−1		13.2k	0.65	3.7	200*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	235	
★	〃 1538	〃	RF. ConV. Mix Osc.AF. PA.LN	〃	50	40	30	150	125	1	30	330	3	0.5	6	−1	NF=3dB (f=1kHz)	13.2k	0.65	3.7	200*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	235	
★	〃 1539	〃	RF. ConV.Mix Osc.AF.PA	〃	25	20	30	150	125	1	15	330	3	0.5	6	−1		13.2k	0.65	3.7	200*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	235	
★	〃 1540	〃	RF. ConV. Mix Osc.AF.PA.LN	〃	25	20	30	150	125	1	15	330	3	0.5	6	−1	NF=3dB (f=1kHz)	13.2k	0.65	3.7	200*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	235	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{iv}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1541	ローム	RF. Conv. Mix Osc. AF. PA	Si. EP	40	32	150	300	125	1	24	330	3	10	6	−1		25.9k	0.8	7.7	250*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	235	
★	〃 1542	〃	〃	〃	25	20	150	300	125	1	15	330	3	10	6	−1		25.9k	0.8	7.7	250*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	235	
★	〃 1543	〃	SW. AF	〃	40	32	20	150	125	1	24	220	3	10	6	−1		20k	0.585	5.8	t_{on}<200ns, t_{off}<300ns t_{stg}<200ns			235	
★	〃 1544	〃	〃	〃	25	20	20	150	125	1	15	220	3	10	6	−1		20k	0.585	5.8	t_{on}<200ns, t_{off}<300ns t_{stg}<200ns			235	
	〃 1545	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	40	32S	300	300	125	1	24	10,000	5	100	5	−10					250*	3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	235	
★	〃 1546	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA. SW	〃	25	20S	300	300	125	1	15	10,000	5	100	5	−10					250*	3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	235	
★	〃 1547	松下	RF	Si. P	30	20	20	150	175	1	25	100	10	2	10	−3	G_{pb}=16dB, NF=4dB (f=800MHz, I_C=3mA)				900*	1.1	60*	50C	
★	〃 1548	東芝	PA	Si. EP	50	25	5A	45W (T_c=25°C)	175	1mA	20	50	5	1A			P_o=23W (f=260MHz, V_{CC}=20V, P_i=4W)							135	
★	〃 1549	富士通	AF	〃	150		50	750	175	1	140	150	5	10							130*	20	70*	247	
★	〃 1550	松下	PA	Si. TP	250	250	100	10W (T_c=25°C)	150	100	250	100	50	5	30	−20					100*	3.5	15	236	
★	〃 1551	東芝	LN	Si. EP	20	15	30	200	175	0.1	10	70	10	10	10	−10	G_{pe}=7dB NF=45dB (f=4GHz, I_C=5mA)				6.5GHz*	0.7	15*	237	
★	〃 1552	〃	〃	〃	20	15	30	250	175	0.1	10	70	10	10	10	−10	G_{pe}=10.5dB NF=3.5dB (f=2GHz, I_C=5mA)				4.5GHz*	0.8	15*	237	
★	〃 1553	〃	〃	〃	20	20	30	175	175	0.1	10	100	10	5	10	−10	G_{pe}=15dB NF=1.2dB (f=500MHz, I_C=3mA)				4.5GHz*	0.9	40*	50C	○
★	〃 1554	〃	RF	〃	30	15	120	1.2W (T_c=25°C)	175	1	10	100	5	50	10	−50	G_{pe}=12.5dB (f=1GHz, I_C=30mA)				4GHz*	1.7	15*	238	
★	〃 1555	〃	〃	〃	30	15	120	1.2W (T_c=25°C)	175	1	10	100	5	50	10	−50	G_{pe}=12.5dB (f=1GHz, I_C=30mA)				4GHz*	1.7	15*	239	
★	〃 1556	〃	〃	〃	30	15	120	1.2W (T_c=25°C)	175	1	10	100	5	50	10	−30	G_{pe}=14dB (f=500MHz)				3.5GHz*	2	25*	85B	
★	〃 1557	〃	PA	〃	40	20	180	3W (T_c=25°C)	175	1	10	150	5	50	18	−50	P_o=1.1W (f=1GHz, V_{CC}=18V, P_i=0.3W)				3GHz*	2.2	10*	85B	
★	〃 1558	〃	LN	〃	15	8	80	250	175	0.1	10	75	8	50	5	−30	G_{pe}=10dB (f=2GHz)				7GHz*	1.1	20*	237	
★	〃 1559	〃	〃	〃	15	8	80	400	175	0.1	10	75	3	50	5	−30	G_{pe}=10dB (f=2GHz)				7GHz*	1.1	20*	238	
	〃 1560	日電	RF	Si. E	25	12	70	580	200	1	15	70	10	20	10	−20	$\|S_{21e}\|^2$=6.5dB (10V, 20mA, 2GHz)				4500*	C_{re} 0.6		190	
	〃 1561	富士通	PA	Si. EP	55	35	500	7W (T_c=25°C)	175	100	20	50	5	200	12	200	P_o=3W (f=700MHz, V_{CC}=28V, P_i=0.5W)				1.8GHz*	4.5		246	
	〃 1562	〃	〃	〃	55	35	1A	12W (T_c=25°C)	175	200	20	50	5	500	12	300	P_o=9W (f=700MHz, V_{CC}=28V, P_i=2W)				1.6GHz*	7		246	
	〃 1563	〃	〃	〃	55	35	2A	25W (T_c=25°C)	175	400	20	50	5	1A	12	500	P_o=15W (f=700MHz, V_{CC}=28V, P_i=4W)				1.2GHz*	12		246	
	〃 1564	〃	〃	〃	55	35	4A	40W (T_c=25°C)	175	800	20	50	5	3A	12	700	P_o=30W (f=700MHz, V_{CC}=28V, P_i=10W)				800*	23		246	
★	〃 1565	松下	PA	Si. P	150	150	1A	10W (T_c=90°C)	150	30	60	120	10	100	10	−50					120*	<10	15	236	2SA795とコンプリ
★	〃 1566	〃	RF	Si. TP	250	250R	100	4W (T_c=25°C)	150	1mA	250	100	20	4	10	−3	35	300	0.4	2.7	100*	3.2	$C_c r_{bb'}$ 60ps	222	○
	〃 1567	〃	PA	Si. EP	100	100	500	1.2W	150	1	100	160	10	150	10	−50					120*	11		222	2SA794とコンプリ
	〃 1568	〃	〃	〃	18	18	1A	4W (T_c=25°C)	150	0.1	18	200	2	500	6	−50					150*	12		222	2SA900とコンプリ
	〃 1569	東芝	〃	Si. T	300	300	150	12.5W (T_c=25°C)	150	1	100	40~170	10	50	10	−30					100*	5	10	268	
	〃 1570	三洋	LN	Si. EP	55	50	100	200	125	0.1	18	160~960	6	1	6	−1	NF=1.5dB (f=100Hz, V_{CE}=6V, I_C=0.1mA)				100*	3	$C_c r_{bb'}$ 250ps	138	2SA929とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie} real* (Ω)	外形	備考
2SC1571	三洋	LN	Si. EP	40	35	100	200	125	0.1	18	160~960	6	1	6	−1	NF=1.5dB (f=100Hz, V_{CB}=6V, I_C=0.1mA)				100*	3	$C_c r_{bb'}$ 250ps	138	2SA930とコンプリ
★ 〃 1572	三菱	RF	〃	90	90	50	150	125	0.1	50	600	6	1	6	−1	600	18k	0.8	10	100*	2	$C_c r_{bb'}$ 100ps	8 A	2SA797とコンプリ
〃 1573	松下	AF	Si.TP	250	250	70	600	135	2	12	120	10	5	10	−3	35	300	0.4	2.7	80*	5	$C_c r_{bb'}$ 60ps	294	2SA879とコンプリ
★ 〃 1574	東芝	LN	Si.EP	20	20	30	400	175	0.1	10	70	10	5	10	−10	G_{pe}=15dB, NF=12dB, 4.5GHz (f=500MHz) (f=500MHz, I_C=3mA)					11.5	20*	85B	
★ 〃 1575	富士通																							
〃 1576	東芝	SW	Si. T	450	330	8 A	100W (T_c=25℃)	150	100	450	30~150	5	1 A			t_{on}=1μs, t_f=0.8μs t_{stg}=3μs							102	
★ 〃 1577	サンケン	〃	Si.TMe	500	400	8 A	80W (T_c=25℃)	150	1mA	500	30	4	3 A	12	−500					7*	55	4*	102	
★ 〃 1578	〃	〃	〃	600	500	8 A	80W (T_c=25℃)	150	1mA	600	30	4	3 A	12	−500					7*	55	4*	102	
★ 〃 1579	〃	PA	〃	500	400	15A	150W (T_c=25℃)	150	1mA	500	20	4	5 A	12	−500					7*	80	3*	102	
★ 〃 1580	〃	〃	〃	600	500	15A	150W (T_c=25℃)	150	1mA	600	20	4	5 A	12	−500					7*	80	3*	102	
★ 〃 1581	東芝	PA	Si. EP	65	35	7 A	80W (T_c=25℃)	175	3mA	30	30	10	5 A			P_o=50W (f=30MHz, V_{cc}=28V, P_i=2W)							223	
★ 〃 1582	〃	〃	〃	65	35	13A	140W (T_c=25℃)	175	6mA	30	30	10	10A			P_o=100W (f=30MHz, V_{cc}=28V, P_i=8W)							223	
〃 1583	三菱	Diff. LN	〃	50	50	100	200 unit	125	0.1	25	250 800	6	−1	6	−1	ΔV_{BE}=10mVmax h_{FE}小/h_{FE}大=0.8~1.0				100*	3.0		274B	2素子複合
★ 〃 1584	サンケン	PA	Si.TMe	150	100	15A	150W (T_c=25℃)	150	1mA	150	60	4	5 A	12	−500	t_r=1.3μs t_{stg}=2μs	t_f=1μs			10*	110	10*	102	2SA907とコンプリ
★ 〃 1585	〃	〃	〃	200	150	15A	150W (T_c=25℃)	150	1mA	200	60	4	5 A	12	−500	t_r=1.3μs t_{stg}=2μs	t_f=1μs			10*	110	10*	102	2SA908とコンプリ
★ 〃 1586	〃	〃	〃	250	200	15A	150W (T_c=25℃)	150	1mA	250	60	4	5 A	12	−500	t_r=1.3μs t_{stg}=2μs	t_f=1μs			10*	110	10*	102	2SA909とコンプリ
★ 〃 1587	三菱	〃	Si. EP	45	45R	3 A	50W (T_c=25℃)	175	1mA	30	50	25	200			P_o=30W (f=295MHz, V_{cc}=23V, P_i=6W)							323	
〃 1588	日電	〃	Si. E	36	18	300	1.7W (T_c=25℃)	125	100	30	55	10	100	10	−30	P_o=0.4W (f=225MHz, V_{cc}=12V, P_i=10mW)				900*	<10		167B	
★ 〃 1589	〃	〃	〃	36	18	700	2.5W (T_c=25℃)	150	100	30	15~200	10	300	10	−50	P_o=1.5W (f=225MHz, V_{cc}=12V, P_i=0.2W)				700*	<15		167B	
★ 〃 1590	〃	〃	〃	36	18	1.2A	13.5W (T_c=25℃)	175	1mA	30	15~200	10	500	10	−300	P_o=6.5W (f=225MHz, V_{cc}=12V, P_i=0.7W)				400*	<25		226	
★ 〃 1591	〃	〃	〃	36	18	2.5A	30W (T_c=25℃)	175	2mA	30	15~200	10	1 A	10	−500	P_o=15.5W (f=225MHz, V_{cc}=12V, P_i=4W)				250*	<50		226	
★ 〃 1592	〃	〃	〃	30	18	100	3.5W (T_c=25℃)	200	0.1	20	100	10	50	10	−50					2700*	C_{re} 1		129	
★ 〃 1593	〃	RF	〃	40	20	150	4.375W (T_c=25℃)	200	50	20	15~200	10	70	10	−70					2000*	2.5		129	
★ 〃 1594	〃	PA	〃	35	18	200	7 W (T_c=25℃)	200	10	20	60	10	100	10	−100	G_{pe}10.5dB (f=1GHz, V_{CB}=15V, I_C=100mA)				2500*	C_{re} 2.8		129	
★ 〃 1595	〃	〃	〃	35	22	300	7 W (T_c=25℃)	200	10	20	60	10	100	10	−100	G_{pe}=3.5dB (f=2.3GHz, V_{CC}=18V, P_i=30dBm)				2500*	C_{re} 2.8		129	
★ 〃 1596	富士通	RF	Si.EP	150	120	50	450	175	1	140	60	5	10	5	−10	t_{on}<1μs, t_{off}<10μs t_{stg}<9.5μs				130*	2	70*	55C	
★ 〃 1597	〃	AF	〃	150		50	450	175	1	140	150	5	10							130*	20	70*	182C	
★ 〃 1598	日電																							
★ 〃 1599	〃																							
★ 〃 1600	〃	RF	Si. E	40	20	250	4.375W (T_c=25℃)	200	100	20	15~200	10	100	10	−100	P_{osc}=28.5dBm (f=1.7GHz, V_{bb}=−18V)				2000*	C_{re} 3		315	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC1601	新日無	RF. AF. LN	Si.EP	35	30	100	200	175	0.05	20	150	6	1	6	−0.1	NF=2dB (f=1kHz)	50k	5	15	200*	2	$C_c r_{bb'}$ 60ps	243		
★	〃 1602	〃	RF. AF	〃	35	30	100	150	125	0.05	20	150	6	1	6	−0.1		50k	5	15	200*	2	$C_c r_{bb'}$ 60ps	27		
★	〃 1603	三菱	PA	〃	18	9	600	6 W (T_c=25°C)	175	100	10	50	7	100			P_o=1.5W (f=485MHz, V_{cc}=7.2V, P_i=0.3W)							312		
★	〃 1604	〃	〃	〃	18	8.5	300	5 W (T_c=25°C)	175	30	10	40	7	50			P_o=0.35W (f=485MHz, V_{cc}=7.2V, P_i=50mW)							255		
★	〃 1605	〃	〃	〃	35	17	3.5A	30W (T_c=25°C)	175	500	25	50	10	100			P_o=16W (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=1.7W)							113		○
★	〃 1606	〃	PA	〃	40	18	600	6 W (T_c=25°C)	175	100	25	50	10	100			P_o= 3 W (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=0.2W)							271		
	〃 1607	富士通	RF	Si.EP	40	20	100	180	175	100	20	50	5	50	12.5	−10	G_{pe}=12dB (f=200MHz)					4		50C		
	〃 1608	〃	PA	〃	40	20	500	5 W (T_c=25°C)	175	100	20	50	5	200			P_o=1.6W (f=470MHz, V_{cc}=12.5V, P_i=0.3W)					5		231		
	〃 1609	日電	SW	Si. EMe	140	120	25A	120W (T_c=25°C)	175	10	140	30	2	13A			t_{on}<0.5μs, t_{off}<2μs t_{stg}<1.5μs							102		
	〃 1610	〃	〃	〃	150	100	10A	100 W (T_c=25°C)	175	100	100	60	5	5 A			t_{on}<0.5μs, t_{off}<2μs t_{stg}<1.5μs							102		
★	〃 1611	〃																								
★	〃 1612	〃																								
	〃 1613	ローム	SW	Si. TP	130	130	30	150	125	1	80	56~270	3	5	5	−2					60*	6		235		○
	〃 1614	〃	〃	〃	180	180	30	150	125	1	120	56~270	3	5	5	−2					60*	6		235		
	〃 1615	〃	〃	〃	210	210	30	150	125	1	150	56~270	3	5	5	−2					60*	6		235		
★	〃 1616	東芝																								
	〃 1617	〃	PA	Si. T	300	100	7 A	50W (T_c=25°C)	150	1mA	250	30~150	5	1 A	5	−500					10*	100		102	水平偏向用	
★	〃 1618	サンケン	〃	Si.TMe	80	60	6 A	50W (T_c=25°C)	150	1mA	80	60	4	3 A	12	−500					10*	85	12*	102	2SA807 とコンプリ	
★	〃 1619	〃	〃	〃	100	80	6 A	50W (T_c=25°C)	150	1mA	100	60	4	3 A	12	−500					10*	85	12*	102	2SA808 とコンプリ	○
★	〃 1620	松下	PA	Si.EP	36	18	600	10W (T_c=25°C)	175	100	15	50	13.5	100	13.5	−150	P_o=2.6W, G_{pe}=6.34dB (f=500MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=0.6W)				1200*	7		227		
	〃 1621	日電	SW	Si.E	25	20S	200	200	150	0.1	30	80	0.5	1	10	−10	t_{on}<20ns, t_{off}<40ns t_{stg}<20ns				500*	3		176		
★	〃 1622	〃	RF. AF	〃	40	35	100	150	125	0.05	25	500	3	0.5	6	−1					100*	3.5	50	176		○
	〃 1623	〃	〃	〃	60	50	100	200	150	0.1	60	200	6	1	6	−10					250*	3	25*	176	2SA812 とコンプリ	
	〃 1624	東芝	PA	Si. P	120	120	1 A	15W (T_c=25°C)	150	1	50	70~240	5	150	5	−150					30*	20		268	2SA814 とコンプリ	
	〃 1625	〃	〃	〃	100	100	1 A	15W (T_c=25°C)	150	1	50	70~240	5	150	5	−150					30*	20		268	2SA815 とコンプリ	
	〃 1626	〃	〃	Si.E	80	80	750	15W (T_c=25°C)	150	0.5	30	70~240	2	150	2	−150					100*	15		268	2SA816 とコンプリ	
	〃 1627	〃	〃	〃	80	80	300	600	150	0.1	50	70~240	2	50	2	−50					150*	6		138	2SA817 とコンプリ	○
★	〃 1628	〃	〃	Si.T	180	150	50	1 W	150	1	100	70~240	5	10	10	−10					120*	<5		249	2SA818 とコンプリ	
★	〃 1629	サンケン	PA	Si.TMe	90	70	6 A	50W (T_c=25°C)	150	1mA	90	1000	4	1 A	12	−500					10*	95	80*	102		
★	〃 1630	ソニー	RF	Si. E PaMe	175	175	30	750	175	1	25	100	5	3	10	−2		$\lvert h_{fe} \rvert$=1 dB (f=100MHz)				3	$C_c r_{bb'}$ 40 ps	181		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1631	ソニー	RF.LN	Si.PaMe	25	25	200	250	100	0.2	25	200	3	1	6	−0.1	170	36k	2.4	3.3	h_{fe}=3dB (f=100MHz)	4.5	$C_c r_{bb'}$ 300ps	138	
★	〃 1632	〃	〃	〃	50	50	200	320	120	0.2	25	200	3	1	6	−2					h_{fe}=1.0dB (f=100MHz)	4.5	$C_c r_{bb'}$ 300ps	138	
★	〃 1633	〃	〃	〃	25	25	200	320	120	0.2	25	200	3	1							h_{fe}=1.4dB (f=100MHz)	4.5	$C_c r_{bb'}$ 300ps	138	
★	〃 1634	〃	〃	〃	50	50	200	320	120	0.2	25	200	3	1	6	−2					h_{fe}=1.0dB (f=100MHz)	4.5	$C_c r_{bb'}$ 300ps	138	
	〃 1635	富士通	SW	Si.EP	70	50	1 A	800	175	0.3	40	50	1	500			t_{on}<35ns, t_{off}<55ns t_{stg}<50ns							123	
★	〃 1636	ソニー	LN.SW	Si.E	50	25	20	300	120	0.2	50	500~2000	3	1	6	−2		NF= 2 dB (6V, 0.1mA, f=10Hz)			30*	4		138	
★	〃 1637	〃	〃	〃	50	25	20	250	120	0.2	50	66~525	3	1	10	−1					20*	4	$C_c r_{bb'}$ 30ps	138	
	〃 1638	富士通	RF	Si.EP	40	20	300	600	175	0.5	20	100	10	20	10	−20					1400*	3	40	85C	
★	〃 1639	ローム	RF.AF	〃	25	20	30	250	125	1	15	270	3	0.5	5	−10					200*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	138	
★	〃 1640	〃	RF.LN	〃	25	20	30	250	125	1	15	560	3	0.5	5	−10	NF= 3 dB (5V, 1mA, f=1kHz)				200*	3	$C_c r_{bb'}$ 120ps	138	
★	〃 1641	〃	RF.AF	〃	40	32	150	300	125	1	24	390	3	10	5	−20					250*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138	
★	〃 1642	〃	〃	〃	25	20	150	300	125	1	15	390	3	10	5	−20					250*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138	
★	〃 1643	〃	AF.SW	〃	40	32	30	250	125	1	24	220	3	10				t_{on}<200ns, t_{off}<300ns t_{stg}<200ns						138	
★	〃 1644	〃	〃	〃	25	20	30	250	125	1	15	220	3	10				t_{on}<200ns, t_{off}<300ns t_{stg}<200ns						138	
	〃 1645	〃	AF	〃	40	32	300	300	125	1	24	>1000	5	100	5	−10					250*	3		138	ダーリントン
★	〃 1646	〃	〃	〃	25	20	300	300	125	1	15	>1000	5	100	5	−10					250*	3		138	ダーリントン
★	〃 1647	〃	AF.SW	〃	50	40	30	250	125	1	30	270	3	0.5	5	−10					200*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	138	
★	〃 1648	〃	RF.LN	〃	50	40	30	250	125	1	30	560	3	0.5	5	−10	NF= 3 dB (5V, 1mA, f=1kHz)				200*	3	$C_c r_{bb'}$ 120ps	138	
	〃 1649	〃	SW	Si.TP	130	130	30	250	125	1	80	56~270	3	5	5	−2					60*	6		138	
	〃 1650	〃	〃	〃	180	180	30	250	125	1	120	56~270	3	5	5	−2					60*	6		138	
	〃 1651	〃	〃	〃	210	210	30	250	125	1	150	56~270	3	5	5	−2					60*	6		138	
	〃 1652	〃	AF.SW	Si.EP	40	32	500	300	125	1	20	82~390	3	100	5	−20					250*	6.2		235	2SA874 とコンプリ
	〃 1653	日電	RF.SW	Si.E	150	130	50	150	125	0.1	130	200	3	15	10	−10					120*	2.3	15	176	
	〃 1654	〃	〃	〃	180	160	50	150	125	0.1	130	200	3	15	10	−10					120*	2.3	15	176	
	〃 1655	〃	RF	〃	16	8	30	150	175	0.1	10	100	3	10	6	−20					8000*	C_{rc} 0.5	40*	320	
	〃 1656	〃	〃	〃	10	6	30	150	200	0.1	10	100	3	10	5	−20					7000*	C_{rc} 0.4	40*	320	
	〃 1657	〃	RF.SW	〃	16	8	30/unit	150/unit	175	0.1	10	100	3	10	6	−20	h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0				8000*	C_{rc} <0.5		307A	2素子複合
	〃 1658	〃	〃	〃	10	6	30/unit	150/unit	200	0.1	10	100	3	10	5	−20	h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0				7000*	C_{rc} <0.5		307A	〃
	〃 1659	〃	RF	Si.E	20	10	80	500	200	0.1	10	100	5	30	6	−30	$\|S_{21e}\|^2$=13dB (f=1GHz, V_{CE}=6V, I_C=30mA)				7000*	C_{rc} 0.6	18*	190	
	〃 1660	〃	〃	〃	20	8	80	500	200	0.1	10	100	5	30	6	−30	$\|S_{21e}\|^2$=13dB (f=1GHz, V_{CE}=6V, I_C=30mA)				7000*	C_{rc} 0.6	18*	190	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC1661	日電	Diff	Si.E	20	10	80	500/unit	175	0.1	10	100	5	30	6	−30	h_{FE1}/h_{FE2}=0.6～1.0 ΔV_{BE}<30mV				7000*	1	18*	308	2素子複合
	〃 1662	〃	〃	〃	20	8	80	350/unit	175	0.1	10	100	5	30	6	−30	h_{FE1}/h_{FE2}=0.6～1.0 ΔV_{BE}<30mV				7000*	0.6	18*	307A	2素子複合
★	〃 1663	ソニー	PF. PA	〃	140	140	500	950	120	0.2	100	60～350	2	100	10	−20					50*	15	$C_c r_{bb'}$ 190ps	174	2SA835とコンプリ
★	〃 1664	サンケン	PA	Si.TMe	70	60	6 A	40W (T_c=25°C)	150	10	70	1200	4	1 A	10	−0.5A					10*	75	12	99	○
★	〃 1665	日電	RF. LN	Si. E	25	13	20	200	175	0.05	12	120	8	5	8	−5		NF=3dB (f=30MHz, 8V, 5mA)			1400*	0.5	40*	85B	
★	〃 1666	〃	RF	〃	40	35	300	600	175	0.05	35	80	14	55	14	−55		KF_2=52dB KF_3=84dB			700*	2	25*	85B	
★	〃 1667	松下	RF.PA	Si.EMe	90	90	4 A	50W (T_c=25°C)	150	1 mA	50	100	4	1 A	10	−0.5A					10*	120	10	102	2SA837とコンプリ
★	〃 1668	東芝	PA	Si.EP	35	18	6 A	40W (T_c=25°C)	175	1 mA	15	40	5	1 A	10	−200					400*	60	3*	135	
	〃 1669	〃	〃	Si. T	150	150	1.5A	25W (T_c=25°C)	150	20	100	40～240	10	500	10	−500					6*	40		268	2SA839とコンプリ
★	〃 1670	ソニー	AF. RF	Si. E	140	140	500	750	120	0.2	100	50～350	2	100	10	−20					50*	15		294	
★	〃 1671	東芝																							
	〃 1672	日電	SW	Si.EMe	150	120	25 A	120W (T_c=25°C)	175	10	150	30	2	13 A			t_{on}<0.5μs t_{off}<1μs t_{stg}<1.5μs							102	
	〃 1673	〃	PA	Si.E	35	20	300	7 W (T_c=25°C)	200	5	20	60	10	100	10	−100	Gpe=3.5dB (f=2.3GHz, V_{cc}=18V, P_i=1W)				2500*	C_{re} 2.8		129	
	〃 1674	〃	RF. Conv Mix.Osc	〃	30	20	20	250	125	0.1	30	90	6	1	6	−1					600*	1	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138	
	〃 1675	〃	〃	〃	50	30	30	250	125	0.1	50	90	6	1	6	−1					250*	1.9	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138	
★	〃 1676	東芝	PA	Si. EP	50	25	3 A	30W (T_c=25°C)	175	100	20	40	5	1 A	10	−300	P_o=12W (f=270MHz, V_{cc}=20V, P_i=1W)				300*	25	5*	260	
★	〃 1677	〃	〃	Si. E	50	25	5 A	45W (T_c=25°C)	175	200	20	40	5	1 A	10	−400					260*	50	3*	260	
★	〃 1678	〃	〃	〃	65	65R	3 A	10W (T_c=25°C)	150	10	30	>15	5	500	5	−100					>100*	30	5	268	
★	〃 1679	〃	〃	〃	65	65R	1.5A	10W (T_c=25°C)	150	10	30	30	5	500	5	−100					550*	20	5	268	
★	〃 1680	〃	〃	Si. EP	35	18	2 A	15W (T_c=25°C)	175	100	15	50	5	1 A		−100	P_o= 8 W (f=175MHz, V_{cc}=135V, P_i=0.5W)				400*	19	10*	135	
★	〃 1681	〃	LN	〃	60	60	50	200	125	0.1	35	450	6	2		−1	450	11.8k	0.89	6.3	130*	NF=3dB (f=10Hz)		33	
★	〃 1682	〃	〃	〃	40	40	50	200	125	0.1	35	450	6	2	6	−1	450	11.8k	0.89	6.3	130*	NF=1.5dB (f=100Hz)		33	
★	〃 1683	松下	PA	Si.TMe	200	150	500	30W (T_c=25°C)	150	10	200	120	10	400	10	−200					6*	35	25	268	2SA843とコンプリ ○
	〃 1684	〃	RF.AF	Si.EP	30	25	100	400	150	1	10	250	10	2	10	−2	250	5000	0.4	20	150*	3.5	70	138	
	〃 1685	〃	〃	〃	60	50	100	400	150	1	10	250	10	2	10	−2	250	5000	0.4	20	150*	3.5	70	138	
	〃 1686	〃	RF	Si.P	40	30	25	400	150	10	40	80	10	−4	10	−4					330*	1	$C_c r_{bb'}$ 45ps	138E	
	〃 1687	〃	〃	Si.EP	40	25	30	400	150	10	40	100	10	7	10	−5					550*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 80ps	138E	
	〃 1688	〃	〃	〃	50	40	30	400	150	10	50	100	10	7	10	−5					550*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 80ps	138E	
★	〃 1689	三菱	PA	〃	55	35	3 A	45W (T_c=25°C)	175	1 mA	40	50	10	100			P_o=26W (f=220MHz, V_{cc}=28V, P_i=5W)							323	
★	〃 1690	オリジン																							

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SC1691	オリジン																								
★	1692	〃																								
★	1693	〃																								
★	1694	〃																								
★	1695	〃																								
★	1696	〃																								
★	1697	〃																								
★	1698	〃																								
★	1699	〃																								
★	1700	〃																								
★	1701	〃																								
★	1702	〃																								
★	1703	〃																								
★	1704	〃																								
★	1705	〃																								
	1706	日立	SW	Si. T	200	150	50	200	175	0.1	100	30~300	6	10	6	−10	t_{on} = 150ns, t_{off} = 1.5μs t_{stg} = 2μs				>60*	<10		49C		
	1707	〃	AF.SW	Si. E	40	30	100	200	175	0.5	20	100~500	1	10	10	−10	t_{on} = 80ns, t_{off} = 300ns t_{stg} = 220ns				>100*	2.6		49C		○
	1708	三菱	AF. LN. RF	Si.EP	90	90	50	200	125	0.1	50	250~1200	6	1	6	−1	V_{NO} < 170mV (10V, 1mA, R_G = 100kΩ, A_v = 80dB)				150*	1.8		138B	2SA847とコンプリ	○
	1709	富士通	SW	〃	30	30R	300	300	150	0.015	10	60	1	10			t_r = 10μs t_f = 25μs t_{stg} = 100μs							275		
★	1710	〃	RF	〃	15	10	130	1 W (Tc=25°C)	175	0.5	10	80	6	60	6	−60					7GHz*	0.8	20*	261		
★	1711	〃	LN	〃	20	13	30	200	175	0.5	10	80	8	10	8	−10	G_{pe} = 10dB, NF = 3dB (f = 2GHz, 8V, 5mA)				7.5GHz*	0.25	30*	262		○
	1712	〃	RF	〃	16	8	30	200	175	0.5	10	80	3	10	6	−15					8GHz*	0.3	30*	262		
	1713	〃	Diff	〃	16	8	30	200	175	0.5	10	80 h_{FE1}/h_{FE2} = 0.6~1.0	3	10	6	−15	ΔV_{BE} < 20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$ < 60μV/℃ (3V, 10mA)				8GHz*	0.45	40*	263		
★	1714	〃	〃	〃	16	8	30	200	175	0.5	10	80 h_{FE1}/h_{FE2} = 0.6~1.0	3	10	6	−15	ΔV_{BE} < 20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$ < 60μV/℃ (3V, 10mA)				8GHz*	0.45	40*	264A		
	1715	〃	〃	〃	16	8	30	200	175	0.5	10	80 h_{FE1}/h_{FE2} = 0.6~1.0	3	10	6	−15	ΔV_{BE} < 20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$ < 60μV/℃ (3V, 10mA)				8 GHz*	0.45	40*	264B		
	1716	〃	〃	〃	16	8	30	200	175	0.5	10	80 h_{FE1}/h_{FE2} = 0.6~1.0	3	10	6	−15	ΔV_{BE} < 20mV, γV_{BE} < 60μV/℃ (3V, 10mA)				8GHz*	0.45	40*	264A		
★	1717	東芝	PA	〃	40	20	1 A	10W (Tc=25°C)	175	1	15	50	5	100	10	−50	P_o = 2.2W (f = 220MHz, V_{cc} = 10V, I_E = 50mA)				600*	6.5	25*	97C		
★	1718	〃	〃	〃	35	18	4.5A	30W (Tc=25°C)	175	100	15	50	5	1.5A	10	−200	P_o = 14W (f = 220MHz, V_{cc} = 13.5V, P_i = 1.5W)				600*	35	4*	135		
★	1719	富士通	RF	Si. EP	150		50	1 W	175	1	140	150	5	10	5	−10					130*	2		90	2SA848とコンプリ	
★	1720	〃	〃	〃	150		50	1 W	175	1	140	150	5	10	5	−10					130*	2		90	2SA849とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC1721	富士通	RF	Si. EP	80	60	1 A	500	150	1	60	35	2	500	10	−50					>100*			138	
★	〃 1722	日立	PA	Si. T	300	300	200	12.5W (Tc=25°C)	150	0.1	250	50~300	10	50	20	−30					80*	4.3	20*	268	
★	〃 1723	〃	〃	〃	300	300	200	15W (Tc=25°C)	150	0.1	250	40~200	10	50	20	−30					60*	6.2	20*	268	
★	〃 1724	東芝	〃	Si. EP	35	17	800	7.5W (Tc=25°C)	175	500	15	100	5	500	10	−100	Po=4 W (f=470MHz, Vcc=12.6V, Pi=0.4W)				2000*	10	4*	135	
★	〃 1725	〃	〃	〃	35	17	1.4A	15W (Tc=25°C)	175	1mA	15	100	5	1 A	10	−100	Po=7 W (f=470MHz, Vcc=12.6V, Pi=1W)				1600*	15	3.5*	135	
★	〃 1726	〃	〃	〃	35	17	2.8A	30W (Tc=25°C)	175	1.5mA	15	100	5	1.5A	10	−100	Po=13W (f=470MHz, Vcc=12.6V, Pi=3W)				1200*	25	3*	135	
★	〃 1727	ソニー	RF. Conv. MIX. Osc. LN	Si. E	35	35	25	300	100	0.2	15	50~350	10	4	10	−4	NF=3.2dB (200MHz, 12V, 4mA)				700*	1.2	Cc rbb' 10ps	138C	フォワードAGC
★	〃 1728	〃	RF. PA	〃	100	50	1 A	950	120	0.2	25	250	2	100	2	−10					80*	16	Cc rbb' 300ps	174	
	〃 1729	三菱	PA	Si. EP	35	17	3.5A	35W (Tc=25°C)	175	1mA	25	50	10	100			Po=16W (f=175MHz, Vcc=13.5V, Pi=1.4W)							272A	
	〃 1730	日電	Osc. Mjx	Si. E	30	15	50	250	125	0.1	12	100	10	5	10	−5					1100*	<1.5	Cc rbb' 10ps	138	
	〃 1731	〃	Diff. SW	〃	20	12	50	300	200	0.1	10	30~300	5	10	5	−15					3000*	1.1		309A	素子複合
	〃 1732	〃	〃	〃	20	12	50/unit	200/unit	200	0.05	10	30~300	5	10	5	−15	hFE1/hFE2=0.8~1.0				3000*	Cre 0.9	30*	309A	2素子複合
	〃 1733	〃	Diff.	〃	30	14	50	300	200	0.05	15	80	10	10	10	−10					2000*	1.1		310	2素子複合
	〃 1734	日立	LN	〃	40	30	30	100	150	0.1	20	160~500	6	0.1	5	−0.1	270	12k	2.5	24				49C	
★	〃 1735	三菱	AF. Drive	〃	100	100	500	800	125	1	50	50~300	10	10	10	−10					130*	7		242	2SA850とコンプリ
★	〃 1736	〃	RF. AF	Si. EP	50	50	100	500	125	0.1	25	400	5	2	5	−10					300*	2	Cc rbb' 100ps	138F	
★	〃 1737	〃	〃	〃	35	35	100	500	125	0.1	25	500	5	2	5	−10					300*	2	Cc rbb' 100ps	138F	
★	〃 1738	〃	RF. AF. LN	〃	35	35	100	500	125	0.1	25	600	5	2	5	−10	NF=0.5dB (6 V, 1mA, 1kHz)				300*	2	Cc rbb' 100ps	138F	
★	〃 1739	ローム	RF. AF	〃	20	16	32	250	125	1	12	180	6	1	6	−1					300*	2	Cc rbb' 45ps	138	
	〃 1740	〃	AF. RF Osc. SW	〃	50	40	100	300	125	0.5	30	120~820	6	1	12	−2					180*	2		138	2SA933とコンプリ
	〃 1741	〃	AF. SW	〃	40	32	500	400	125	1	20	82~390	3	100	5	−20					250*	6.2		138	2SA854とコンプリ ○
★	〃 1742	東芝	LN	〃	20	10	30	150	175	0.1	10	120	5	10	5	−10	NF=3.5dB(2GHz, 5V, 5mA) Gpe=11.5dB(2GHz, 5V, 10mA)				6500*	0.66	15*	237	
★	〃 1743	〃	〃	〃	20	15	30	175	175	1	10	70	10	10	10	−10	NF=3.5dB(2GHz, 10V, 5mA) Gpe=10dB(2GHz, 10V, 10mA)				4500*	0.75	12*	280	
★	〃 1744	〃	PA	〃	35	18	10A	70W (Tc=25°C)	175	2mA	15	50	5	2 A	10	−400	Po=44W (f=175MHz, Vcc=13.5V, Pi=10W)				200*	110	1*	193	
★	〃 1745	〃	RF. LN	〃	60	60	50	150	150	0.1	35	450	6	2	6	−1	NF=3dB (f=10Hz, VCE=6V, IC=0.1mA)				140*	2	60	49C	
★	〃 1746	〃	〃	〃	50	50	50	150	150	0.1	35	450	6	2	6	−1	NF=1.5dB (f=100Hz, VCE=6V, IC=0.1mA)				140*	2	60	49C	○
	〃 1747	日立	RF	Si. EPa	40	20	100	300	175	1	10	25~250	10	20	10	−20					>1400*	Cre <2	60*	50C	
	〃 1748	日電	SW	Si. T	300	300	100	800	150	1	300	60	2	50	30	−10	ton=0.3μs, toff=0.5μs tstg=3.5μs				50*	4.2		84C	
	〃 1749	三菱	PA	Si. TP	300	220	100	10W (Tc=25°C)	150	1	150	130	10	25	10	−10					80*	3.5	Cc rbb' 45ps	180	
★	〃 1750	三洋																							

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1751	三洋																							
	〃 1752	モトローラ	RF	Si. E	300	300	500	625	150	0.1	200	125	10	10	20	−10	モトローラ MPSA42 相当				80 *	1.7	$C_c r_{bb'}$ 300ps	138D	
	〃 1753	〃	〃	〃	200	200	500	625	150	0.1	160	125	10	10	20	−10	〃 MPSA43 〃				80 *	1.7	$C_c r_{bb'}$ 300ps	138D	
★	〃 1754	〃	〃	〃	40	40	500	625	150	0.05	30	100k	5	10	5	−10	JEDEC 2N6426 〃				240 *	5.4	1 M *	138D	
	〃 1755	三洋	PA	Si.TP	300	300	200	15W (T_c=25°C)	150	0.1	200	40~200	10	10	30	−10					>50 *	<5.3		268	
	〃 1756	〃	〃	〃	300	300	200	15W (T_c=25°C)	150	0.1	200	40~200	10	10	30	−10					>50 *	<5.3		300	
	〃 1757	〃	〃	〃	300	300	200	15W (T_c=25°C)	150	0.1	200	40~200	10	10	30	−10					>50 *	<5.3		267	
★	〃 1758	日電	RF	Si. T	300	300	100	10W (T_c=25°C)	150	1	300	120	10	20	20	−10					80 *	< 3		104	
★	〃 1759	〃																							
★	〃 1760	ソニー	RF. PA	Si. E	100	50	1 A	950		0.2	25	250	2	100	2	−10					80 *	16	$C_c r_{bb'}$ 300ps	174B	
★	〃 1761	〃	〃	〃	20	16	2 A	950	120	0.1	16	320	2	100	2	−10					80 *	30	$C_c r_{bb'}$ 300ps	174B	2SA861 とコンプリ
★	〃 1762	〃	SW	Si. T	700	400	300	470	150	2	100	50	5	10	5	−10	t_c=350ns t_{stg}=600ns t_r=250ns t_f=250ns				13 *	8.5	$C_c r_{bb'}$ 200ps	181	2SA911 とコンプリ
	〃 1763	東芝	PA	Si. EP	65	35	7 A	80W (T_c=25°C)	175	3mA	30	>10	10	5 A	15	−100	P_o=45W(PEP) (f=30MHz. V_{CC}=28V. P_i=1W)				>50 *	110		281	
	〃 1764	〃	〃	〃	65	35	12A	140W (T_c=25°C)	175	6mA	30	>10	10	10A	15	−200	P_o=85W(PEP) (f=30MHz. V_{CC}=28V. P_i=2.84W)				>50 *	220		281	
	〃 1765	〃	〃	〃	35	17	800	7.5W (T_c=25°C)	175	1mA	15	>10	5	500			P_o=3.2W (f=470MHz. V_{CE}=12.6V. P_i=0.6W)					<15		97C	エミッタ・ケース接続
	〃 1766	日立	AF	Si.EPa	30	30	100	310	125	0.5	18	600	12	2	12	−2	NF=4dB (1kHz. 6V. 0.1mA)				230 *	1.8		138D	2SA1033 とコンプリ
★	〃 1767	〃																							
★	〃 1768	サンケン	PA	Si.TMe	200	150	5 A	50W (T_c=25°C)	150	100	200	1000	4	1 A	12	−100					15 *	50	100 *	102	
★	〃 1769	新日無	RF. LN	Si. EP	30	25	50	200	125	0.05	20	250	6	1	6	−0.1		50k	5	15	200 *	2	$C_c r_{bb'}$ 60ps	138D	
★	〃 1770	〃	RF. AF	〃	30	25	200	300	125	0.1	20	250	6	1	6	−1		5k	1	20	100 *	5	$C_c r_{bb'}$ 40ps	138D	
★	〃 1771	〃	RF	〃	60	50	200	300	125	0.1	20	250	6	1	10	−2					100 *	5	$C_c r_{bb'}$ 40ps	138D	
★	〃 1772	〃	〃	〃	95	90	50	300	125	0.1	20	250	6	1	10	−2					40 *	5	$C_c r_{bb'}$ 40ps	138D	
★	〃 1773	〃	〃	〃	30	30	400	500	125	0.5	20	200	1	100	10	−5					100 *	6	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138D	
★	〃 1774	〃	〃	〃	60	50	400	500	125	0.5	20	200	1	100	10	−5					100 *	6	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138D	
	〃 1775	日立	〃	Si. E	90	90	50	300	150	0.5	75	400~1200	12	2	12	−2					200 *	1.6		138	2SA872 とコンプリ ○
	〃 1776	富士通	〃	Si. EP	60	40	200	300	150	0.5	40	150	1	10	10	−10					220 *	3	40 *	275	
★	〃 1777	サンケン	PA	Si.EMe	70	70	6 A	50W (T_c=25°C)	150	1mA	70	60	4	5 A	12	−500					10 *	90	12 *	102	
	〃 1778	松下	RF. Conv. Osc	Si. P	25	20	15	400	150	100	25	50	10	3	10	−3					650 *	1	30 *	138E	
	〃 1779	〃	RF	〃	30	20	20	400	150	100	30	50	10	2	10	−2					675 *	1.5	60 *	138E	フォワードAGC
★	〃 1780	〃	〃	Si.EP	25	18	15	150	125	100		50	10	2	10	−3					3000 *	1.5	20	276	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	r_{bb} h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC1781	日立	RF	Si. E	70	50	500	350	175	0.5	50	80~240	3	10	3	−10	t_{on}=35ns, t_{off}=350ns t_{stg}=300ns				150*	6	350*	49C	2SA876とコンプリ
	〃 1782	サンケン	PA	Si.TMe	140	80	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	140	60	4	3A	12	−500					10*	165	13*	102	
★	〃 1783	〃	〃	〃	180	120	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	180	60	4	3A	12	−500					10*	165	13*	102	
	〃 1784	〃	〃	〃	150	150	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	150	20	4	5A			t_r<1.5μs t_f<1μs t_{stg}<4μs							102	
	〃 1785	〃	〃	〃	200	200	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	200	20	4	5A			t_r<1.5μs t_f<1μs t_{stg}<4μs							102	
★	〃 1786	〃	〃	〃	230	230	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	230	20	4	5A			t_r<1.5μs t_f<1μs t_{stg}<4μs							102	
★	〃 1787	松下	RF. LN	Si. EP	35	35	30	150	125	0.1	10	540	5	2	10	−1	NF=6dB (100Hz, 10V, 200μA)				150*	2.2	70	276	2SA880とコンプリ
	〃 1788	〃	PA	〃	25	20	500	625	150	10	25	160	2	500	10	−50					150*	6	3.5k	138	2SA1128とコンプリ ○
	〃 1789	〃	RF. Mix. Conv. Osc	〃	25	18	50	400	150	0.1	25	100	10	2	10	−10					1200*	1.05	20	138	
★	〃 1790	〃	RF	〃	25	18	15	150	175	100	25	50	10	2	10	−3					3000*	1.2	20	50C	
★	〃 1791	日電	PA	Si. E	45	23	1A	11W (Tc=25°C)	200	500	30	60	10	500	10	−300	P_o=6W (f=1GHz, V_{CC}=18V, P_i=2W)				1200*	Cre<7		184	
	〃 1792	〃	〃	〃	45	23	2A	22W (Tc=25°C)	200	1mA	18	60	10	500	10	−600	P_o=10W (f=1GHz, V_{CC}=18V, P_i=4W)				800*	Cre<14		184	
	〃 1793																								
	〃 1794																								
	〃 1795																								
	〃 1796																								
★	〃 1797	日電	PA	Si. E	50	50R	300	6W (Tc=25°C)	200	200	28	60	10	100			P_o=1.6W, η=33% (f=2GHz, V_{CC}=28V, P_i=0.5W)					Cre<3		118B	
★	〃 1798	〃	〃	〃	50	50R	1A	11.6W (Tc=25°C)	200	500	28	60	10	150			P_o=3.1W, η=35% (f=2GHz, V_{CC}=28V, P_i=0.5W)					Cre<6		118B	
★	〃 1799	〃	〃	〃	50	50R	2A	19.5W (Tc=25°C)	200	500	28	60	10	200			P_o=6.3W, η=33% (f=2GHz, V_{CC}=28V, P_i=1W)					Cre<9		118B	
★	〃 1800	〃	〃	〃	50	50R	3A	29W (Tc=25°C)	200	500	28	60	10	500			P_o>10W, η=35% (f=2GHz, V_{CC}=28V, P_i=3.2W)					Cre<10		118B	
★	〃 1801	新日無	RF	Si. EP	30	15	30	150	125	0.5	15	60	10	5	10	−10					1300*	1	$C_c r_{bb}$ 6ps	138D	
★	〃 1802	〃	〃	〃	30	15	20	150	125	0.5	15	60	6	2	10	−2					700*	1	$C_c r_{bb}$ 2.5ps	138D	
	〃 1803	日電	RF.LN	Si. E	30	18	130	580	200	0.1	20	100	5	50	5	−50					2700*	Cre 1	15*	190	
★	〃 1804	三菱	PA	Si. EP	47	47R	1A	10W (Tc=25°C)	175	200	30	50	25	100			P_o=4.5W (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_i=1W)							273	
★	〃 1805	〃	〃	〃	45	45R	2A	30W (Tc=25°C)	175	1mA	35	50	25	100			P_o=12W (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_i=3.5W)							273	
★	〃 1806	〃	〃	〃	45	45R	4A	50W (Tc=25°C)	175	2mA	35	50	25	200			P_o=26W (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_i=8W)							273	
★	〃 1807	〃	RF. PA	〃	18	8.5	0.1A	300	175	30	10	10~180	7.2	20			P_o=25mW (f=485MHz, V_{CC}=7.2V, P_{in}=5mW)							50C	
★	〃 1808	〃	〃	〃	35	17	1A	10W (Tc=25°C)	175	100	15	10~180	10	0.1A			P_o=3.5W (f=485MHz, V_{CC}=13.5V, P_{in}=0.4W)							312	
	〃 1809	ローム	RF. Mix Osc. Conv	〃	25	20	20	150	125	0.5	20	39~180	6	1	6	−1					500*	1.4		138	
★	〃 1810	ソニー	PA	Si. T	700	300	300	950	120	2	12	50	5	10	10	−10					13*	8.5	$C_c r_{bb}$ 170ps	174B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1811	ソニー	RF	Si. E	240	150	100	750	120	0.2	100	150	5	3	10	−20	|h_{fe}|=8dB (f=100MHz)					2.4	$C_c r_{bb'}$ 45ps	294	2SA896とコンプリ
★	〃 1812	〃	〃	〃	22	22	20	210	100	0.2	15	80	10	3	10	−3	NF=3.7dB (f=800MHz, V_{CB}=10V, I_C=3mA)				1100*	0.75	$C_c r_{bb'}$ 3.5ps	305A	フォワードAGC
★	〃 1813	〃	〃	Si. E PaMe	50	50	500	500	120	0.2	49	200	2	100	10	−10					100*	8	$C_c r_{bb'}$ 110ps	138D	
★	〃 1814	東芝																							
	〃 1815	〃	AF	Si. E	60	50	150	400	125	0.1	60	70~700	6	2	10	−1	NF= 1 dB (f= 1 kHz, 6 V, 0.1mA)				>80*	2	50	138	2SA1015とコンプリ
★	〃 1816	ソニー	RF. PA	Si. E PaMe	100	60	4 A	16W (T_c=25°C)	150	1	50	100	2	100	10	−100	P_o= 6 W (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.4W)				140*	45	$C_c r_{bb'}$ 35ps	268	
★	〃 1817	〃	PA	Si.E	45	20	5 A	25W (T_c=25°C)	150	2	40	60	2	100	10	−1 A	P_o= 20W (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=1W)				250*	80		268	
★	〃 1818	松下	PA	Si.EMe	130	130	7 A	100W (T_c=25°C)	150	500	70	150	5	7 A	10	−500					7*	400	10	102	2SA882とコンプリ
	〃 1819	〃	〃	Si. TP	300	300	100	15W (T_c=25°C)	150	10	300	100	10	30	30	−20					100*	4.5	15	268	
	〃 1820	富士通	RF. PA	Si. EP	55	35	500	3 W (T_c=25°C)	175	100	20	50	5	200			P_o=1.6W (f=175MHz)					4		84B	
	〃 1821	〃	〃	〃	55	35	500	7 W (T_c=25°C)	175	100	20	50	5	200			P_o= 4 W (f=470MHz)					4.5		246	
	〃 1822	〃	〃	〃	55	35	1 A	12W (T_c=25°C)	175	200	20	50	5	500			P_o=7.5W (f=470MHz)					7		246	
	〃 1823	〃	〃	〃	55	35	2 A	25W (T_c=25°C)	175	400	20	50	5	1 A			P_o=15W (f=470MHz)					12		246	
	〃 1824	〃	〃	〃	55	35	4 A	40W (T_c=25°C)	175	800	20	50	5	3 A			P_o=30W (f=470MHz)					23		246	
	〃 1825	〃	〃	〃	55	35	8 A	75W (T_c=25°C)	175	1.6mA	20	50	5	6 A			P_o=55W (f=470MHz)					45		329	
	〃 1826	サンケン	PA	Si.TMe	80	60	4 A	30W (T_c=25°C)	150	1mA	80	100	4	1 A	12	−200					10*	40	20*	298	2SA768とコンプリ
	〃 1827	〃	〃	〃	100	80	4 A	30W (T_c=25°C)	150	1mA	100	100	4	1 A	12	−200					10*	40	20*	298	2SA769とコンプリ
★	〃 1828	〃	〃	〃	800	400	1 A	40W (T_c=25°C)	150	100	800	70	10	200	10	−100					7*	20	12*	99	
★	〃 1829	〃	〃	〃	200	150	5 A	100W (T_c=25°C)	150	1mA	200	1000	4	1 A	12	−500					15*	50	100*	102	
★	〃 1830	〃	〃	〃	140	140	15A	150W (T_c=25°C)	150	100	140	>500	2	8 A	12	−500					10*			102	ダーリントン
★	〃 1831	〃	〃	〃	90	70	8 A	100W (T_c=25°C)	150	1mA	90	1000	4	1 A	12	−500					10*	100	40*	102	ダーリントン
★	〃 1832	〃	〃	〃	500	400	15A	150W (T_c=25°C)	150	100	500	300	2	10A	12	−500					7*	130	40*	102	ダーリントン
★	〃 1833	日電	RF.SW	Si.E	60	40	200	300	150	0.1	40	160	1	10	10	−10	t_{on}=45ns t_{off}=250ns t_{stg}=190ns				300*	3.5		138	
★	〃 1834	〃	〃	〃	40	20	200	300	150	0.1	30	120	1	10	10	−10	t_{on}<20ns, t_{off}<40ns t_{stg}<20ns				500*	4	120	138	
★	〃 1835	三菱																							
★	〃 1836	〃																							
★	〃 1837	富士通	PA	Si.EP	35	20	600	7.5W (T_c=25°C)	175	400	20	50	5	200			P_o= 1 W (f=2GHz, V_{CC}=18V, P_i=0.2W)							166	
★	〃 1838	〃	〃	〃	35	20	1.5A	15W (T_c=25°C)	175	1mA	20	50	5	500			P_o= 3 W (f=2GHz, V_{CC}=18V, P_i=1W)							166	
★	〃 1839	日電																							
	〃 1840	〃	AF	Si. E	40	35	100	500	125	0.05	40	400	6	1	6	−1					100*	<8		138	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC1841	日電	RF. AF	Si. E	120	120	50	500	125	0.05	120	400	6	1	6	−1					110*	1.6		138	
〃 1842	〃	RF. LN	〃	40	35	100	250	125	0.1	60	600	6	1	6	−10	NF=1.2dB (6V, 1mA, 100Hz)				250*	3	50*	138	
〃 1843	〃	〃	〃	60	50	100	250	125	0.1	60	400	6	1	6	−1	NF=0.8dB (6V, 1mA, 100Hz)				110*	3.5	50*	138	
〃 1844	〃	AF. LN	Si. E	60	60	100	500	125	0.05	60	400	6	1	6	−1	V_{NO}<45mV (5V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				100*	4.8		138	2SA991とコンプリ
〃 1845	〃	〃	〃	120	120	50	500	125	0.05	120	600	6	1	6	−1	V_{NO}<40mV (5V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				110*	1.6		138	2SA992とコンプリ
〃 1846	松下	PA	Si. EP	45	35	1 A	1.2W	150	0.1	20	160	10	500	10	−50					200*	15		222	2SA885とコンプリ
〃 1847	〃	〃	〃	50	40	1.5A	1.2W	150	1	20	120	5	1 A	5	−500					150*	35		222	2SA886とコンプリ
〃 1848	〃	〃	〃	70	50	2 A	1.2W	150	1	40	130	5	1 A	5	−500					150*	50		161	2SA887とコンプリ
〃 1849	〃	RF. AF	〃	30	25	100	350	135	1	10	250	10	2	10	−2	250	5 k	0.4	20	150*	3.5	70	138D	
〃 1850	〃	〃	〃	60	50	100	350	135	1	10	250	10	2	10	−2	250	5 k	0.4	20	150*	3.5	70	138D	
〃 1851	〃	PA	〃	30	25	500	625	135	0.1	20	160	10	150	10	−50					200*	6	3.5 k*	138D	2SA890とコンプリ
〃 1852	〃	〃	〃	60	50	500	625	135	0.1	20	160	10	150	10	−50					200*	6	3.5 k*	138D	2SA891とコンプリ
〃 1853	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	30	20	30	250	125	1	10	250	10	1	10	−1					230*	1.3	35	138	
〃 1854	〃	RF. AF	〃	30	25	50	250	125	1	10	200	5	2	5	−2	220	5 k	0.4	20	150*	2.2	70	138	
〃 1855	日立	RF	Si. Pa	20	20	20	250	150	0.1	20	20~200	10	2	10	−2	G_{pe}=28dB (V_{CC}=12V, I_C=4mA, f=45MHz)				550*	C_{re} 0.35		138C	フォワードAGC
〃 1856	〃	〃	〃	20	20	20	250	150	0.1	20	20~200	10	2	10	−2	G_{pe}=22dB (V_{CC}=12V, I_C=2mA, f=200MHz)				550*	C_{re} 0.35		138C	フォワードAGC
★ 〃 1857	〃	〃	Si. T	300	300	100	800	150	1	250	100	20	20	20	−20					80*	3	20*	84B	
★ 〃 1858																								
★ 〃 1859	ソニー	RF	Si. E PaMe	25	20	1.5A	500	120	0.2	25	180	2	100	10	−10					140*	15	$C_c r_{bb'}$ 250ps	138	
〃 1860	日電	SW	Si. E	150	100	2 A	800	150	1	100	70	5	100			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1μs							84B	
〃 1861	〃	〃	〃	300	250	2 A	800	150	10	250	60	5	100			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs							84B	
〃 1862	〃	〃	Si. T	450	400	2 A	800	150	10	400	40	5	100			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							84B	
〃 1863	〃	〃	Si. E	150	100	7 A	40W (T_c=25°C)	150	100	100	>20	5	3 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs							134	
〃 1864	〃	〃	〃	300	250	7 A	40W (T_c=25°C)	150	100	250	>20	5	3 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs							134	○
〃 1865	〃	〃	Si. T	450	400	7 A	40W (T_c=25°C)	150	100	400	>15	5	3 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs							134	
〃 1866	〃	〃	〃	150	100	7 A	80W (T_c=25°C)	150	100	100	>20	5	3 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs							102	
〃 1867	〃	〃	Si. E	300	250	7 A	80W (T_c=25°C)	150	100	250	>20	5	3 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs							102	○
〃 1868	〃	〃	Si. T	450	400	7 A	80W (T_c=25°C)	150	100	400	>15	5	3 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs							102	
〃 1869	〃	〃	〃	150	100	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	100	>20	5	5 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs							102	
〃 1870	〃	〃	〃	300	250	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	250	>20	5	5 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs							102	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1871	日電	SW	Si.EMe	450	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	5 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs							102	○
★	〃 1872	〃	〃	〃	150	100	30A	200W (Tc=25°C)	175	100	100	30~120	5	10A										106	
★	〃 1873	〃	〃	〃	300	200	30A	200W (Tc=25°C)	175	100	250	20~120	5	5 A										106	
★	〃 1874	〃	〃	〃	500	400	30A	200W (Tc=25°C)	175	100	400	20~80	5	3 A										106	
★	〃 1875	〃	〃	〃	1500	500	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	20	1000	19	10	500			t_f<1μs t_{stg}<10μs							102	
	〃 1876	日立	RF.SW	Si.E	100	70	500	800	175	100	100	>2000	10	100			t_{on}=0.1μs, t_{off}=0.6μs							84B	ダーリントン
★	〃 1877	〃																							
★	〃 1878	〃																							
	〃 1879	〃	RF.SW	Si.E	120	120	2 A	800	175	100	120	>1000	2	2 A			t_{on}=0.5μs, t_{off}=4.2μs							84B	ダーリントン ダンパ内蔵
★	〃 1880	〃	〃	〃	120	120	2 A	15W (Tc=25°C)	150	0.1	100	4000	2	2 A			t_{on}<1μs, t_{off}<8μs t_{stg}<5μs							268	ダーリントン
	〃 1881	〃	〃	〃	60	60	3 A	30W (Tc=25°C)	150	200	60	>1000	1.5	1.5A			t_{on}=1μs, t_{off}= 5 μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
★	〃 1882	〃	〃	〃	120	120	5 A	800	175	1	100	5000	5	5 A	10	−100	t_{on}<0.6μs, t_{off}<3μs t_{stg}<2μs				46 *	29	15	85B	ダーリントン 端子接続が異なる
★	〃 1883	〃	〃	〃	120	120	5 A	30W (Tc=25°C)	150	1	100	4000	2	5 A	10	−1A	t_{on}<2μs, t_{off}<16μs t_{stg}<10μs				10 *	80	10	268	ダーリントン
★	〃 1884	〃	〃	〃	120	120	8 A	40W (Tc=25°C)	150	1	100	>1000	2	8 A			t_{on}=2.2μs, t_{off}=10μs							153	ダーリントン
★	〃 1885	松下	RF	Si.EP	150	150	50	750	135	1	100	150	5	10	10	−10					200 *	2	3.5k *	294	2SA912 とコンプリ
	〃 1886	日立	RF.Mix.Osc	〃	30	19	50	200	125	0.5	10	80	10	10	10	−10					1000*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138	
	〃 1887	〃	RF.Osc	〃	30	19	50	200	125	0.5	10	80	10	10	10	−10					1100*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138	
★	〃 1888	サンケン	PA	Si.TMe	80	60	3 A	800	150	100	80	1000	5	100	5	−100					15 *	35	250 *	84B	
★	〃 1889	〃	〃	〃	100	80	3 A	800	150	100	100	1000	5	100	5	−100					15 *	35	250 *	84B	
	〃 1890	日立	AF	Si.E	90	90	50	300	150	0.5	75	250~1200	12	2	12	− 2					200 *	1.6		138	2SA893 とコンプリ ○
★	〃 1891	東芝	PA	Si.TMe	1200	1200S	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	500	10	−100		t_f< 1 μs			3 *	45		102	水平偏向用
★	〃 1892	〃	〃	〃	1500	1500S	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	1 A	10	−100		t_f< 1 μs			3 *	95		102	水平偏向用
★	〃 1893	〃	〃	〃	1500	500	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	1 A	10	−100		t_f< 1 μs			3 *	95		102	水平偏向用
★	〃 1894	〃	〃	〃	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	2 A	10	−100		t_f< 1 μs			3 *	155		102	水平偏向用
★	〃 1895	〃	〃	〃	1500	600	6 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	2 A	10	−100		t_f< 1 μs			2 *	165		102	水平偏向用
★	〃 1896	〃	〃	〃	1500	600	7 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	2 A	10	−100		t_f< 1 μs			2 *	165		102	水平偏向用
★	〃 1897	新日無	RF	Si.EP	30	25	1 A	600	125	0.5	20	200	1	100	10	−50					200 *	20	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138	
★	〃 1898	〃	〃	〃	30	15	30	200	125	0.5	20	90	6	1	10	− 2					500 *	0.9	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	138C	
★	〃 1899	〃	〃	Si.P	30	25	20	200	125	0.5	20	90	6	1	10	− 2					500 *	0.9	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	138C	
★	〃 1900	〃	RF.LN	〃	120	120	50	300	125	0.05	20	300	6	1	6	−0.1		50 k	5	15	90 *	2	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	r_{bb} h_{ie} real* (Ω)	外形	備考	
	2SC1901	富士通	RF	Si.EP	25		20	200	175	0.1	12	150	8	5							1400*	1.2	40*	84C		
	〃 1902	〃	〃	〃	40		300	500	175	0.1	35	80	14	55							650*	2.8	25*	84C		
	〃 1903	〃	AF. RF	〃	150	120	50	1 W	150	1	140	150	5	10	5	−10					130*	2	70*	328		
	〃 1904	〃	〃	〃	150	150	50	1 W	150	1	140	150	5	10	5	−10					130*	2	70*	328		
	〃 1905	松下	PA	Si.TP	350	300	200	15W (T_c=25°C)	150	10	300	100	10	50	30	−20					45*	7.5	10	268		
	〃 1906	日立	RF. Conv.	Si. EP	30	19	50	300	150	0.5	10	>40	10	10	10	−10	C_{rpe}=18dB (10V, 5mA, 200MHz)				1000*	1	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138		
	〃 1907	〃	Osc. RF	〃	30	19	50	300	150	0.5	10	>40	10	10	10	−10	P_{OSC}= 8 mW (f=930MHz, V_{CB}=10V, I_C=10mA)				1100*	1	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138		
★	〃 1908	ソニー	RF	Si. E	30	30	30	500	120	1	25	80	6	1	6	−1					200*	2	$C_c r_{bb'}$ 25ps	138	2SA925 とコンプリ	
★	〃 1909	日電	PA	〃	75	75R	3 A	10W (T_c=25°C)	150	10	40	60	10	500	10	−150	P_o=5.5W (f=27MHz, V_{cc}=12V, P_i=0.2W)				160*	50	4	268		
★	〃 1910	東芝	Diff	Si. EP	15	8	80	200/unit	175	0.1	5	75	3	50	5	−30	ΔV_{BE}<30mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<0.2mV/°C (3V, 50mA)				7000*	1.1	15*	282A		
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.8～1.0														
★	〃 1911	〃	〃	〃	20	10	30	150/unit	175	0.1	10	80	5	10	5	−10	ΔV_{BE}<15mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<0.1mV/°C (5V, 10mA)				6500*	0.66	15*	282A		
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.8～1.0														
★	〃 1912	〃	〃	〃	20	10	30	150/unit	175	0.1	10	80	5	10	5	−10	ΔV_{BE}<15mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<0.1mV/°C (5V, 10mA)				6500*	0.66	15*	282B		
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.8～1.0														
★	〃 1913	松下	RF	〃	150	150	1 A	15W (T_c=25°C)	150	10	130	150	10	150	10	−50					120*	20		268	2SA913 とコンプリ	○
	〃 1914	三菱	AF. RF	〃	90	90	50	200	125	0.1	50	250～1200	6	1	6	−1					150*	1.8		138B		○
★	〃 1915	〃	〃	〃	120	120	50	800	135	1	100	150～800	10	10	10	−10					200*	2.3		242	2SA905 とコンプリ	
★	〃 1916	〃	RF.AF.LN	〃	50	50	100	200	125	0.1	35	500	6	1	6	−1	NF=0.5dB (6V, 1mA, 1kHz)				150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138		
★	〃 1917	〃	〃	〃	35	35	100	200	125	0.1	25	500	6	1	6	−1	NF=0.5dB (6V, 1mA, 1kHz)				150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138		
★	〃 1918	〃	RF. AF	〃	35	35	100	200	125	0.1	25	500	6	1	6	−1	500	16k	1.1	20	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138		
★	〃 1919	〃	LN	〃	50	50	30	200	125	0.1	50	250～1200	6	1	6	−1	NF=0.9dB (6V, 100μA, 10Hz)				150*	1.9		138B		
★	〃 1920	東芝	Diff	〃	15	8	80	200/unit	175	0.1	5	75	3	30	5	−30	ΔV_{BE}<30mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<0.2mV/°C (3V, 50mA)				7000*	1.1	15*	282B		
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.8～1.0														
	〃 1921	日立	RF	Si. T	250	200	50	600	150	1	120	30～300	6	10	6	−10					130*	3	25*	251		
	〃 1922	〃	SW	〃	1500	800	2.5A	50W (T_c=25°C)	150	10	600				5	−400	t_f< 1μs				5*	90	15	102	水平偏向用	
	〃 1923	東芝	RF. Conv. Mix. Osc	Si. EP	40	30	20	100	125	0.5	18	40～200	6	1	6	−1	NF=2.5dB (100MHz)				550*	C_{re} 0.7	$C_c r_{bb'}$ <30ps	138		
	〃 1924	日電	Diff.SW	Si.E	20	12	50	300	200	0.1	10	30～300	5	10	5	−15					3000*	C_{re} 1.1		309B	2素子複合	
	〃 1925	〃	〃	〃	20	12	50	300	200	0.1	10	30～300	5	10	5	−15	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8～1.0 ΔV_{BE}<10mV (5V, 10mA)				3000*	C_{re} 1.1		309A	2素子複合	
	〃 1926	〃	〃	〃	30	14	50	200/unit	200	0.05	15	80	10	10	10	−10	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8～1.0				2000*	C_{re} 1.1		309B	2素子複合	
	〃 1927	〃	〃	〃	30	14	50	300	200	0.05	15	80	10	10	10	−10					2000*	C_{re} 1.1		309A	2素子複合	
★	〃 1928	ソニー	RF	〃	50	50	50	315	120	0.2	50	400	3	1	10	−20					35*	4	$C_c r_{bb'}$ 150ps	38		
	〃 1929	松下	PA	Si. P	300	300	400	25W (T_c=25°C)	150	10	300	150	5	100	10	−100					80*	12	15	268		
	〃 1930	富士通	RF	Si. EP	16	8	30	150	175	0.1	10	80	3	10	6	−20					8000*	0.3	30*	284		○

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SC1931	富士通	Diff	Si. EP	16	8	30	150/unit	175	0.1	10	80	3	10	6	−20	ΔV_{BE}<20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (3 V, 10mA)				8000*	0.45	50*	263	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
★	〃 1932	〃	〃	〃	16	8	30	200/unit	175	0.1	10	80	3	10	6	−20	ΔV_{BE}<20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (3 V, 10mA)				8000*	0.45	50*	264A	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
	〃 1933	〃	〃	〃	15	10	40	200/unit	175	0.1	10	80	3	10	6	−20	ΔV_{BE}<20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (6 V, 20mA)				6000*	0.65	50*	263	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
	〃 1934	〃	〃	〃	20	10	80	500/unit	175	0.1	10	80	5	30	6	−30	ΔV_{BE}<30mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (5 V, 30mA)				6000*	0.9	50*	285	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
★	〃 1935	〃	RF	〃	15	10	30	250	175	0.1	10	80	6	10	6	−20					6000*	0.4	25*	284	
★	〃 1936	〃	Diff	〃	15	10	30	200/unit	175	0.1	10	80	6	10	6	−20	ΔV_{BE}<20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (6 V, 10mA)				6000*	0.6	50*	263	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
★	〃 1937	〃	RF	〃	15	10	70	300	175	0.1	10	80	6	40	6	−40					6000*	0.7	20*	284	
★	〃 1938	〃	Diff	〃	15	10	30	200/unit	175	0.1	10	80	6	10	6	−20	ΔV_{BE}<20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (6 V, 10mA)				6000*	0.6	50*	264B	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
★	〃 1939	〃	〃	〃	15	10	30	200/unit	175	0.1	10	80	6	10	6	−20	ΔV_{BE}<20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (6 V, 20mA)				6000*	0.6	50*	264A	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
	〃 1940	日電	PA	Si.E	120	120	50	1 W	150	0.1	120	200	10	10	10	−10					120*	2.3		278	2SA915とコンプリ
	〃 1941	〃	〃	〃	160	160	50	1 W	150	0.1	160	200	10	10	10	−10					120*	2.3		278	2SA916とコンプリ
	〃 1942	日立	SW	Si. T	1500	800	3 A	50W (T_c=25°C)	150	10	600				5	−200	t_f< 1 μs				5*	90	15	102	水平偏向用
★	〃 1943	三菱	PA	Si. EP	35	17	400	3 W (T_c=25°C)	175	100	15	50	10	100			P_o=0.4W (f=470MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=30mW)							255	
	〃 1944	〃	〃	〃	80	40	6 A	20W (T_c=25°C)	150	100	30	50	10	100			P_o=15W (V_{CC}=12V, f=27MHz, P_i=1W)							301B	
	〃 1945	〃	〃	〃	80	40	6 A	20W (T_c=25°C)	150	100	30	50	10	100			P_o=16W, η=70% (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.5W)							301A	
	〃 1946	〃	〃	〃	35	17	7 A	50W (T_c=25°C)	175	2mA	25	50	10	200			P_o=32W, η=70% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=6W)							272A	
	〃 1947	〃	〃	〃	35	17	1 A	10W (T_c=25°C)	175	500	25	50	10	100			P_o= 4 W, η=60% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.3W)							84 B	エミッタ・ケース接続
	〃 1948	日電	RF.LN	Si. E	15	10	20	150	200	1	8	80	8	10	8	−10	G_{pe}=8.5dB (8 V, 10mA, 4 GHz)				8000*	C_{re} 0.3		339	
	〃 1949	〃	〃	〃	30	18	130	580	200	0.1	20	100	5	50	5	−50	$\|S_{21e}\|^2$=9.2dB (5 V, 50mA, 1 GHz)				2700*	C_{re} 1		190	
★	〃 1950	〃	RF.PA	〃	28	14	200	5 W (T_c=25°C)	200	0.5	10	40	6	100	6	−100	$\|S_{21e}\|^2$=4dB (f=1GHz, V_{CE}=6V, I_C=100mA)				4000*	C_{re} 1.5	25*	311	
★	〃 1951	ソニー	RF	〃	120	120	100	750	120	0.2	100	150	5	3	10	−20	h_{fe}=8dB (f=100MHz)					2.4	$C_c r_{bb}$ 45ps	294	2SA917とコンプリ
	〃 1952	日電	RF. LN	〃	45	25	300	800	200	0.1	20	80	10	50	15	−50	G_{pe}=18dB (15V, 50mA, 200MHz)				2000*	2		84B	
★	〃 1953	松下	AF.PA	Si. EP	150	150	100	1 W	150	1	100	65~450	5	10	10	−10					>70*	< 3		222	2SA914とコンプリ
	〃 1954	富士通	RF	〃	25	20	150	450	150	1	20	100	10	25	10	−25					1500*	2	35*	138	
	〃 1955	東芝	PA	〃	35	17	800	7.5W (T_c=25°C)	175	1mA	15	>10	5	500			P_o=3.2W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=0.15W)					<15		84B	
★	〃 1956	〃	〃	〃	35	18	3.5A	35W (T_c=25°C)	175	1mA	15	50	5	1 A			P_o=17W (f=175MHz, V_{CE}=12.5V, P_i=1.3W)							135	
	〃 1957	日電	〃	Si.E	75	40	1 A	750	150	1	40	90	10	500	10	−150	P_o=1.8W, η>60% (V_{CC}=12V, f=27MHz, P_i=35mW)				250*	14	14	225	
★	〃 1958	富士通																							
	〃 1959	東芝	AF. SW	Si. E	35	30	500	500	150	0.1	35	70~240	1	100	6	−20					300*	7		138	2SA562とコンプリ
	〃 1960	富士通	SW	Si. EP	20	15	200	500	150	0.4	15	60	1	10			t_r=4ns, t_f=9ns t_{stg}=6ns							275	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25℃) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (℃)	電気的特性 (T_a = 25℃) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB} (V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE} (V)	I_C (mA)	バイアス V_{CB} (V)	I_E (mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1961	ソニー	RF	Si. E	35	35	25	300	100	0.2	15	100	10	4			|h_{fe}|=17dB (10V, 4mA, 100MHz)					1.2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138C	
★	〃 1962	〃	PA	Si.EPa	200	200	500	950	120	0.2	200	70～350	2	100	10	−20					45*	12		174	
★	〃 1963	〃	RF	Si.PaMe	25	25	200	270	120	0.2	25	300	6	2	6	−2					140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 300ps	277	2素子複合
★	〃 1964	三菱	PA	Si.EP	80		3.5A	12.5W T=25℃	150	500	30	50	10	100			P_o=3.4W (f=27MHz, V_{cc}=12V, P_i=0.4W)							301B	
	〃 1965	〃	〃	〃	35	17	1A	15W T=25℃	175	500	25	50	10	100			P_o=6.5W η=60% (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=0.6W)							97B	エミッタ, ケース接続 ○
	〃 1966	〃	〃	〃	35	17	1A	10W T=25℃	175	100	15	50	10	100			P_o=3.5W η=60% (f=470MHz, V_{cc}=13.5V, V=0.5W)							272A	
	〃 1967	〃	〃	〃	35	17	2A	20W T=25℃	175	200	15	50	10	100			P_o=8W, η=60% (f=470MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=1.5=W)							272A	
	〃 1968	〃	〃	〃	35	17	5A	40W T=25℃	175	500	15	50	10	100			P_o=16W η=60% (f=470MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=6W)							272A	○
	〃 1969	〃	〃	〃	60	25	6A	20W T=25℃	150	100	30	50	12	10			P_o=18W (f=27MHz, V_{cc}=12V, P_i=1W)							301B	
	〃 1970	〃	〃	〃	40	17	600	5W T=25℃	150	100	25	50	10	100			P_o=1.3W η=60% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.12W)							301B	
	〃 1971	〃	〃	〃	35	17	2A	12.5W T=25℃	150	500	25	50	10	100			P_o=7W η=70% (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=0.6W)							301A	
	〃 1972	〃	〃	〃	35	17	3.5A	25W T=25℃	150	1mA	25	50	10	100			P_o=15W η=70% (f=175MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=2.5W)							301A	
★	〃 1973	松下	RF, PA	〃	55	45R	500	1W	150	1	20	20～200	5	100	10	−30	P_O=1W (V_{CC}=13.5V, f=50MHz, P_i=0.03W)				>300*	6		294	
★	〃 1974	〃	PA	〃	80	80R	2A	15W T=25℃	150	10	40	60	5	1A	5	−500	P_o=5W (f=50MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=2.5W)				150*	40	3k*	268	
★	〃 1975	〃	〃	〃	120	90R	2A	15W T=25℃	150	10	40	100	5	1A	5	−500	P_o=3.8W (f=50MHz, V_{cc}=13.5V, P_i=0.5W)				150*	40	3k*	268	
★	〃 1976	〃	RF. PA	〃	36	18	I_{CM} 500	750	135	1	20	70	13.5	100	10	−30	P_o>0.6W, η=60% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.05W)				700*	6		294	
★	〃 1977	〃	〃	〃	36	18	I_{CM} 1A	5W (T_c=25℃)	150	50	20	50	13.5	100	10	−30	P_o>2W, η=60% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.5W)				600*	10		222	
★	〃 1978	〃	〃	〃	36	18	I_{CM} 1.5A	15W (T_c=25℃)	150	100	20	80	13.5	400	10	−300	P_o>7W, η=60% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=1W)				600*	25		268A	
★	〃 1979																								
★	〃 1980	松下	LN	Si. EP	120	120	50	150	125	0.1	50	260～1040	5	2										138	2SA921 とコンプリ
★	〃 1981	ソニー	AF. SW	Si.E	50	30	100	300	120	0.02	50	500～2000	3	1	6	−2	t_d=30ns t_{stg}=600ns t_r=75ns t_f=130ns				30*	4		49C	
★	〃 1982	〃	RF	Si.PaMe	140	140	1A	625	150	0.1	50	120	2	100	10	−10					120*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	181	
	〃 1983	サンケン	PA	Si.TMe	80	60	3A	30W T=25℃	150	100	80	700	4	1A	12	−200					15*	37	150*	298	
	〃 1984	〃	〃	〃	100	80	3A	30W T=25℃	150	100	100	700	4	1A	12	−200					15*	37	150*	298	
	〃 1985	〃	〃	〃	80	60	6A	40W T=25℃	150	1mA	80	100	4	1A	12	−500					10*	80	12*	298	2SA770 とコンプリ
	〃 1986	〃	〃	〃	100	80	6A	40W T=25℃	150	1mA	100	100	4	1A	12	−500					10*	80	12*	298	2SA771 とコンプリ
★	〃 1987	日立	〃	Si. T	300	90	6A	50W (T_c=25℃)	150	10	200	50	5	5A	5	−1A					12*	117	12*	153	
	〃 1988	日電	RF	Si.E	25	12	70	350	200	1	15	70	10	20	10	−20	NF=1.5dB (500MHz, 10V, 3mA)				4500*	C_{re} 0.6	30*	50C	
	〃 1989	松下	〃	Si.EP	30	20	30	150	125	0.1	10	100	10	1	10	−1					300*	1.2	3.5k*	138	
	〃 1990	〃	〃	〃	30	20	15	150	125	1	10	100	6	1	6	−1					650*	1	3.5k*	138	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC1991	日電	RF	Si. E	60	60	100	625	150	0.05	60	170	10	2	6	−10					250*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 40ps	138D	
	〃 1992	〃	RF. AF	〃	50	45	100	300	150	0.06	50	235	5	2	5	−2	238	5 k	5	32	300*	3	$C_c r_{bb'}$ 250ps	138F	
	〃 1993	〃	〃	〃	30	20	100	300	150	0.06	30	290	5	2	5	−2	330	5 k	5	32	300*	3	$C_c r_{bb'}$ 250ps	138F	
	〃 1994	〃	RF.AF.LN	〃	45	30	100	300	150	0.06	45	380	5	2	5	−10	NF=1.5dB (f=1kHz, V_{CE}=5V, I_C=0.2mA)				300*	3	$C_c r_{bb'}$ 250ps	138F	
	〃 1995	〃	〃	〃	50	45	100	300	150	0.06	50	380	5	2	5	−10	NF=1.5dB (f=1kHz, V_{CE}=5V, I_C=0.2mA)				300*	3	$C_c r_{bb'}$ 250ps	138F	
	〃 1996	〃	RF	〃	50	45	800	625	150	0.1	20	200	1	100	5	−10					100*	11	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138F	
	〃 1997	〃	〃	〃	30	20	800	625	150	0.1	20	200	1	100	5	−10					100*	11	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138F	
	〃 1998	〃	RF. AF	〃	80	65	100	500	150	0.05	80	140	5	2	5	−2	320	5 k	4.9	28.5	300*	3.7	$C_c r_{bb'}$ 250ps	138F	
	〃 1999	〃	〃	〃	50	45	100	500	150	0.05	50	140	5	2	5	−2	320	5 k	4.9	28.5	300*	3.7	$C_c r_{bb'}$ 250ps	138F	
	〃 2000	〃	RF	〃	60	50	200	600	150	0.1	60	90	6	1	6	−1					70*	3.7	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	138	
	〃 2001	〃	RF.AF	〃	30	25	700	600	150	0.1	30	200	1	100	6	−10					170*	13	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138	2SA952 とコンプリ
	〃 2002	〃	〃	〃	60	60	300	600	150	0.1	60	200	1	50	6	−10					140*	7	$C_c r_{bb'}$ 25ps	138	2SA953 とコンプリ
	〃 2003	〃	〃	〃	80	80	300	600	150	0.1	80	200	1	50	6	−10					140*	7	$C_c r_{bb'}$ 25ps	138	2SA954 とコンプリ
★	〃 2004	〃																							
★	〃 2005	〃																							
★	〃 2006	〃																							
★	〃 2007	〃																							
★	〃 2008	ソニー	RF	Si. E	35	35	100	300	100	0.2	15	70	3	1	10	−5					560*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	138F	
★	〃 2009	〃	〃	〃	35	35	25	250	100	0.3	15	70	3	1	10	−10					630*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	138C	
★	〃 2010	〃	〃	〃	35	35	30	300	100	0.2	15	70	10	4	10	−4					400*	1	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138C	
★	〃 2011	〃	〃	〃	30	15	50	250	100	0.2	15	50	3	1	10	−8					630*	1.3	$C_c r_{bb'}$ 16ps	138C	
★	〃 2012	〃	〃	〃	30	30	30	500	120	1	25	80	6	1	6	−1					200*	2	$C_c r_{bb'}$ 25ps	138	
★	〃 2013	〃	〃	〃	35	35	25	300	100	0.2	15	100	10	4	10	−4	NF=3dB (12V, 4mA, 200MHz)				700*	1	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138C	
★	〃 2014	〃	LN	Si.EPa	100	50	200	500	120	0.1	50	95~420	3	10	10	−10					100*	7		138	2SA1066 とコンプリ
★	〃 2015	〃																							
★	〃 2016	〃																							
★	〃 2017	三菱	SW	Si. T	450	400	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	450	>10	3	5A	10	−500	t_r=0.4μs, t_f=0.5μs t_{stg}=2.5μs				>10*			102	
★	〃 2018	〃	〃	〃	300	300	15A	100W (T_c=25°C)	150	100	300	>12	3	10A			t_r=0.4μs, t_f=0.6μs t_{stg}=2.4μs							102	
★	〃 2019	〃	〃	〃	300	250	15A	100W (T_c=25°C)	150	100	300	>15	3	10A			t_r=0.4μs, t_f=0.6μs t_{stg}=2.4μs							102	
★	〃 2020	ソニー	RF.PA	Si.E	45	20	2 A	12W (T_c=25°C)	150	2	40	60	2	100	2	−100	P_o=7W, (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.2W)				270*	20		268	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC2021	ローム	AF. RF Osc. SW	Si. EP	50	40	100	300	125	0.5	30	120~820	6	1	12	−2					180*	2		235	2SA937とコンプリ
〃 2022	サンケン	PA	Si. TMe	300	300	1 A	30W (Tc=25°C)	150	1mA	300	100	4	200	12	−100					10*	18	20	298	
〃 2023	〃	〃	〃	300	300	2 A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	300	100	4	500	12	−200	t_r=0.3μs, t_f=1μs t_{stg}=4μs				10*	30	20	298	
〃 2024	富士通	AF. RF	Si. EP	80	60	1 A	1 W	150	0.5	60	70	1	200	10	−30					150*	10	<50*	328	
〃 2025	日電	RF	Si. E	35	18	50	350	200	0.1	20	100	5	25	5	−25	NF=2.6dB (5V, 25mA, 200MHz)				2200*	C_{rc} 1.3		50C	
★ 〃 2026	〃	RF. LN	〃	30	14	50	250	150	0.1	15	100	10	10	10	−10	G_{pe}=15dB (10V, 10mA, 500MHz)				2200*	C_{rc} 0.75		138C	
〃 2027	日立	SW	Si. T	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	600				5	−100	t_f<1.5μs				8*	150	10	102	水平偏向用
〃 2028	富士通	〃	Si. EP	80	45	1.5A	5 W (Tc=25°C)	150	1	30	200	5	100			P_o=0.7W (f=27MHz, V_{CE}=12V, P_i=30mW)					18		328	
〃 2029	〃	〃	〃	80	70	2 A	10W (Tc=25°C)	150	10	30	100	5	100			P_o=6W (f=27MHz, V_{CE}=12V, P_i=0.3W)					60		268	
★ 〃 2030	〃																							
〃 2031	〃	PA	Si. EP	45	23	500	7.5W (Tc=25°C)	175	100	20	50	5	200			P_o=2.5W, η_c=60% (f=470MHz, V_{CC}=21V, P_i=0.3W)					5		330	
〃 2032	〃	〃	〃	45	23	1 A	12.5W (Tc=25°C)	175	200	20	50	5	500			P_o=5.5W, η_c=60% (f=470MHz, V_{CC}=21V, P_i=1W)					8		330	
〃 2033	〃	〃	〃	45	23	3 A	30W (Tc=25°C)	175	600	20	50	5	2 A			P_o=18W, η_c=65% (f=470MHz, V_{CC}=21V, P_i=6W)					18		330	
★ 〃 2034	松下	〃	〃	120	90R	2 A	12W (Tc=25°C)	150	1	40	120	5	1 A	5	−500	P_o=3.8W (f=50MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.5W				150*	40	3k*	84C	
〃 2035	富士通	AF. RF	〃	50	28	300	300	150	0.1	30	80	1	10	10	−10					350*	4	50*	275	
〃 2036	東芝	PA	Si. E	80	80R	1 A	1 W	150	0.1	60	150	2	150	10	−100					150*	12	8*	342	
★ 〃 2037	日電	RF. LN	〃	30	14	50	250	150	0.1	15	80	10	10	10	−10	G_{pe}=13dB (10V, 10mA, 500MHz)				2000*	C_{rc} 0.9		138D	
★ 〃 2038	三菱																							
〃 2039	〃	PA	Si. EP	70	38	8 A	80W (Tc=25°C)	175	1mA	30	50	28	1 A			P_o=50W, η=70% (f=30MHz, V_{CC}=28V, P_i=0.5W)							302	
★ 〃 2040	〃	〃	〃	40	25	500	5 W (Tc=25°C)	175	100	30	50	20	100			G_{pe}=20dB (f=220MHz, V_{CC}=20V, I_C=100mA)							312	
★ 〃 2041	富士通																							
★ 〃 2042	〃																							
★ 〃 2043	〃	RF. PA	Si. EP	60	60	8 A	25W (Tc=25°C)	150	10	30	500	5	500	5	−150	P_o=16W (V_{CC}=12V, f=27MHz, P_i=1W)				220*	70		268	
〃 2044	〃	〃	〃	55	3	6 A	65W (Tc=25°C)	175	1.2mA	20	50	5	5 A			P_o=42W (V_{CC}=28V, f=770MHz, P_i=15W)					3.7		329	
★ 〃 2045	〃																							
★ 〃 2046	日電																							
★ 〃 2047	〃																							
★ 〃 2048	〃																							
★ 〃 2049	〃																							
★ 〃 2050	松下	RF. PA	Si. EP	60	25	I_{CM} 8 A	20W (Tc=25°C)	150	20	40	>20	10	2 A	10	−500	P_o>13W, η>60% (f=50MHz, V_{CC}=12V, P_i=3W)				150*	80		268	
★ 〃 2051	富士通	AF. RF	〃	60	40	250	500	150	0.5	40	150	1	10	10	−10					300*	3	<105*	138	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25℃) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (℃)	電気的特性 (T_a = 25℃) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB} (V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE} (V)	I_C (mA)	バイアス V_{CB} (V)	I_E (mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★ 2SC2052	日電																							
〃 2053	三菱		Si.EP	40	17					15	50	10	10			P_o = 200mW, η = 50% (f = 175MHz, V_{CC} = 13.5V, P_i = 4mW)							242	
★ 〃 2054	〃																							
〃 2055	〃	RF	Si.EP	18	9	300	500	135	30	10	50	7	50			P_o = 250mW, η = 60% (f = 175MHz, V_{CC} = 7.2V, P_i = 10mW)							242	
〃 2056	〃		〃	18	9	600	800	175	100	10	50	7	100			P_o = 2W, η = 60% (f = 175MHz, V_{CC} = 7.2V, P_i = 0.2W)							84B	エミッタ、ケース接続
★ 〃 2057	三洋	RF.LN	Si.TP	30	25	20	250	125	1	25	40~200	6	1	6	−3					500*	C_{re} 0.6	$C_{rbb'}$ 6 pls	138C	
〃 2058	ローム	RF.Conv Mix	Si.EP	40	25	50	250	125	0.5	24	56~270	6	1	6	−1					300*	1.6		138	
〃 2059	〃	RF.Conv Mix.Osc	〃	25	20	20	150	125	0.5	20	39~180	6	1	6	−1					500	1.2		335	
〃 2060	〃	AF	〃	40	32	700	750	125	0.5	20	82~390	3	100	5	−50					150*	15		294	2SA934とコンプリ
〃 2061	〃	〃	〃	80	80	700	750	125	0.5	50	82~390	3	100	10	−50					120*	10		294	2SA935とコンプリ
〃 2062	〃	〃	〃	40	32	300	300	125	0.1	30	>5000	3	100	5	−10					200*	2.5		138	ダーリントン
〃 2063	〃	RF.Conv Mix	〃	40	25	50	250	125	0.5	24	56~270	6	1	6	−1					300*	1.6		235	
★ 〃 2064	富士通																							
〃 2065	日電	PA	Si.E	35	18	250	6 W (T_c=25℃)	200	10	20	100	10	80	10	−80	G_{pe} = 14.5dB (f = 500MHz, V_{CE} = 10V, I_C = 80mA)				3200*	2		129	
★ 〃 2066	〃	〃	〃	35	18	450	7 W (T_c=25℃)	200	20	18	15~200	7	100	7	−100					2000*	<55		129	
★ 〃 2067	富士通	AF.RF	Si.EP	35	35	1 A	500	150	0.5	25	150	1	200	10	−30					150*	<25	<50*	138	
〃 2068	東芝	PA	Si.T	300	300	50	1.5W	150	1	240	30~200	10	20	20	−20					95*	<4	10	178	
〃 2069	富士通	SW	Si.EP	20	17	300	350	175	0.5	10	80	1	10			t_r < 30ns, t_f < 50nls t_{stg} < 50ns							49C	
〃 2070	〃	〃	〃	40	32	300	300	175	0.2	20	70	1	30			t_{on} < 160ns, t_{off} < 172nls t_{stg} < 130ns							49C	
〃 2071	〃	AF.RF	〃	250	220	50	1 W	150	1	200	150	5	10	5	−10					100*	2	70*	328	
★ 〃 2072	ソニー	RF	Si EpaMe	50	25	100	150	85	0.2	25	70	3	1			$\|h_{fe}\|$ = 1.4dB (6 V, 2 mA, 100MHz)					2	$C_{rbb'}$ 40pls	138B	
〃 2073	東芝	RF. PA	Si.T	150	150	1.5A	25W (T_c=25℃)	150	10	120	75	10	500	10	−500					4*	35	25	268	
★ 〃 2074	〃																							
〃 2075	〃	PA	Si.E	80	80R	4 A	10W (T_c=25℃)	150	10	30	>25	5	500	5	−500	P_o > 3.5W (f = 27MHz, V_{CC} = 12V, P_i = 0.3W)				100*	40		268	
〃 2076	松下	RF	Si.EP	35	30	20	200	125	1	20	150	10	1	10	−2					150*	2.5		138	
★ 〃 2077	〃																							
〃 2078	三洋	RF. PA	Si.EP	80	75R	3 A	10W (T_c=25℃)	150	10	40	25~200	5	500	10	−100	P_O > 4W, η > 60% (V_{CC} = 12V, f = 27MHz, P_i = 0.2W)				150*	45		268	
★ 〃 2079	〃	〃	〃	100	80	700	1 W	125	1	20	60~320	5	50	10	−50					100*	10		68	
〃 2080	富士通	SW	〃	60	50	1 A	1 W	150	0.5	40	50	1	500			t_{on} = 35ns, t_f = 55nls t_{stg} = 50ns					8		328	
〃 2081	日電	RF. PA	Si.E	38	18	750	10W (T_c=25℃)	175	250	30	100	10	200	10	−200	P_O = 35dBm, η = 60% (V_{CC} = 12.6V, f = 500MHz, P_i = 25dBm)				1200*	C_{re} 6		129	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ / f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC2082	日電	RF. PA	Si. E	38	18	2.2A	25W (Tc=25°C)	175	750	30	100	10	600	10	−600	P_o=39.5dBm, η=70% (V_{CC}=12.6V, f=500MHz, P_i=34dBm)				550*	Cre 17		43	
〃 2083	〃	〃	〃	38	18	3 A	34W (Tc=25°C)	175	1mA	30	100	10	800	10	−800	P_o=42dBm, η=75% (V_{CC}=12.6V, f=500MHz, P_i=38dBm)				400*	Cre 24		43	
★ 〃 2084																								
〃 2085	松下	PA	Si. TP	300	300R	100	10W (Tc=25°C)	150	10	300	80	10	50	30	−20					55*	8	10	268	
〃 2086	三菱	〃	Si. EP	75	35	1 A	800	135	100	30	70	10	100			P_o=450mW, η=60% (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=15mW)							242	
〃 2087	沖	RF. AF	〃	300	300R	5	100	175	1	30	50	5	1	6	−1	60	1k	0.8	15	80*	5	Cre rbb' 30pS	49C	
★ 〃 2088	東芝	LN	Si. E	120	120	50	300	125	0.1	120	200~700	6	2	6	−1	600	16k	1.2	12	150*	2	40	138	2SA941とコンプリ
★ 〃 2089	〃	〃	〃	120	120	50	300	125	0.1	120	200~700	6	2	6	−1	600	16k	1.2	12	150*	2	40	138	2SA942とコンプリ
★ 〃 2090	日電																							
★ 〃 2091	日立	PA	Si. E	75	40	1 A	750	150	1	40	20~200	10	500	10	−150	P_o=1.8W, η>60% (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=35mW)				>150*	<20		160	
★ 〃 2092	〃	〃	〃	75	75R	3 A	12W (Tc=25°C)	150	10	40	60	10	500	10	−150	P_o=5W, η>60% (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.2W)				250*	40		268	
〃 2093	日電	Osc. PA	〃	28	14	200	5 W (Tc=25°C)	200	0.5	10	40	6	100			$\|S_{21e}\|^2$ = 4 dB (6 V, 100mA, 1 GHz)					Cre 1.5		311	
〃 2094	三菱	PA	Si. EP	40	17	3.5A	30W (Tc=25°C)	175	2 mA	25	50	10	100			P_o=17.5W, η=70% (f=470MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=2 W)							272A	
★ 〃 2095	〃																							
★ 〃 2096	〃																							
〃 2097	〃	RF.PA	Si. EP	50	20	15A	125W (Tc=25°C)	175	5mA	25	50	10	100			P_o=85W, η=65% (f=30MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=4W)							303	
〃 2098	東芝	PA		70	70R	6 A	20W (Tc=25°C)	150	100	40	200~100	5	4 A	5	−500	P_o=15W (f=28MHz, V_{CE}=12V, P_i=1W)				>100*	80		268	
〃 2099	〃	〃	〃	40	18	6 A	60W (Tc=25°C)	175	1.5mA	15	20~185	5	1 A	5	−500	P_o=25W (f=28MHz, V_{CE}=12.5V, P_i=1.1W)				100*	<250		325	
★ 〃 2100	〃	〃	〃	40	18	15A	150W (Tc=25°C)	175	3mA	15	50	5	10A			P_o=60W, PEP (f=28MHz, V_{CE}=12.5V, P_i=3W PEP)							281	
〃 2101	〃	〃	〃	35	18	2 A	15W (Tc=25°C)	175	100	15	>10	5	1 A	10	−100	P_o=8W (f=175MHz, V_{CE}=12.5V, P_i=0.5W)				400*	<25		316	
〃 2102	〃	〃	〃	35	18	3.5A	35W (Tc=25°C)	175	1mA	15	>10	5	1 A			P_o=17W (f=175MHz, V_{CE}=12.5V, P_i=1.3W)					<80		316	
★ 〃 2103	〃	〃	〃	40	18	6 A	50W (Tc=25°C)	175	1mA	15	50	5	1 A			P_o=26W (f=175MHz, V_{CE}=12.5V, P_i=4W)							316	
〃 2104	〃	〃	〃	35	17	800	7.5W (Tc=25°C)	175	1mA	15	150	5	500			P_o=4W (f=470MHz, V_{CE}=12.6V, P_i=0.4W)					10		316	
〃 2105	〃	〃	〃	35	17	1.4A	15W (Tc=25°C)	175	1mA	15	80	5	1 A			P_o=7W (f=470MHz, V_{CE}=12.6V, P_i=1W)					15		316	
〃 2106	〃	〃	〃	35	17	2.8A	30W (Tc=25°C)	175	1.5mA	15	120	5	1.5A			P_o=13W (f=470MHz, V_{CE}=12.6V, P_i=3W)					25		316	
〃 2107	日電	RF	Si. E	60	40	100	150	125	0.1	40	160	1	10	10	−10					300*	3.5	40	176	
★ 〃 2108	〃	〃	〃	120	80	700	800	150	0.5	80	100	2	50	10	−50					250*	10		84B	
★ 〃 2109	〃	RF. SW	Si. E	60	40	200	300	150	0.1	40	160	1	10	10	−10	t_{on}=45nS, t_{off}=250nS t_{stg}=190nS				300*	3.2	40	304	
★ 〃 2110	富士通																							
★ 〃 2111	日電	RF. SW	Si. E	40	20	200	300	150	0.1	30	120	1	10	10	−10	t_{on}<20nS, t_{off}<40nS t_{stg}<20nS				500*	4	120	304	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SC2112	日電																								
★	〃 2113	松下	PA	Si.EP	40	30	1 A	1 W	150	1	20	220	10	50	5	−500					100*	50	3.3k*	222		
★	〃 2114	東芝	RF.LN	〃	15	8	80	225	125	0.1	10	75	3	50	5	−30	G_{pr}=9dB, NF=4dB (f=2GHz, V_{CE}=5V, I_C=30mA)				7000*	1	20*	317		
★	〃 2115	〃	〃	〃	20	10	30	150	125	1	10	120	5	10	5	−10	G_{pr}=9dB, NF=4dB (f=2GHz, V_{CE}=5V, I_C=5mA)				6500*	0.6	15*	317		
★	〃 2116	〃	〃	〃	30	20	50	225	125	1	10	80	10	10	10	−5	G_{pr}=15dB, NF=2.5dB (f=500MHz, V_{CE}=10V, I_C=4mA)				3000*	1.2	40*	317		
	〃 2117	〃	PA	〃	35	17	800	7.5W (T_c=25°C)	175	1mA	15	>10	5	500			P_o=3.2W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=0.15W)					<15		97C	エミッタ・ケース接続	
	〃 2118	〃	〃	〃	35	17	1.4A	10W (T_c=25°C)	175	1mA	15	>10	5	1 A			P_o=6W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=0.6W)					<25		97C	エミッタ・ケース接続	
★	〃 2119	〃	〃	Si.E	80	80R	4 A	12.5W (T_c=25°C)	150	15	40	50	5	2 A			P_o=8 W (f=28MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.4W)							268		
	〃 2120	〃	〃	Si.EP	30	30	800	600	150	0.1	35	100~320	1	100	5	−10					120*	13		138	2SA950とコンプリ	
★	〃 2121	〃	SW	Si.TMe	750	300	3 A	50W (T_c=25°C)	150	I_{CEX} 500	750	15~60	5	1 A	10	−200					8*	85		102		
★	〃 2122	〃	〃	〃	800	325	10A	50W (T_c=25°C)	150	I_{CEX} 1mA	800	>15	10	2.5A	10	−100	t_f<1μs				6*	125		102	水平偏向用	○
★	〃 2123	〃	〃	〃	1000	400	12A	50W (T_c=25°C)	150	I_{CEX} 1mA	1000	>5	5	8 A	10	−500	t_f<1μs				6*	125		102	〃	
★	〃 2124	〃	〃	〃	2200	800	2 A	10W (T_c=25°C)	100	I_{CEX} 1mA	V_{CE} 2200										4*	50		102	〃	
★	〃 2125	〃	PA	Si.TMe	2200	800	5 A	50W (T_c=25°C)	150	500	2200	25	10	1 A	10	−100					5*	165	10	102		
	〃 2126	新電元	SW	Si.T	200	200	3 A	30W (T_c=25°C)	150	250	200	42	3	3 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs, t_{stg}<2μs							204		○
	〃 2127	〃	〃	〃	200	200	10A	100W (T_c=25°C)	150	250	200	32	3	10A			t_{on}<1μs, t_f<1μs, t_{stg}<2μs							102		○
	〃 2128	〃	〃	〃	200	200	30A	200W (T_c=25°C)	150	500	200	22	3	30A			t_{on}<1μs, t_f<1μs, t_{stg}<2μs							266		○
★	〃 2129	三菱	AF.LN.RF	Si.EP	70	70	100	200	125	0.1	50	250~1200	6	1	6	−1	V_{NO}<300mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				100*	3	45	138B		
★	〃 2130	〃	AF.RF	〃	70	70	100	200	125	0.1	50	250~1200	6	1	6	−1					100*	3		138B		
	〃 2131	〃	PA	〃	40	18	600	800	175	100	25	50	10	100			P_o=1.6W, η=60% (f=500MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.3W)							84B	エミッタ・ケース接続	
★	〃 2132	〃	〃	〃	35	17	9 A	50W (T_c=25°C)	175	1mA	15	50	10	1 A			P_o=30W, η=65% (f=470MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=10W)							313	MTH004	
	〃 2133	〃	〃	〃	55	35	5 A	75W (T_c=25°C)	175	2mA	35	50	25	200			P_o=34W, η=60% (f=220MHz, V_{CC}=28V, P_i=4.5W)							313		
	〃 2134	〃	〃	〃	55	35	10A	120W (T_c=25°C)	175	5mA	35	50	25	200			P_o=70W, η=60% (f=220MHz, V_{CC}=28V, P_i=12W)							313		
★	〃 2135	ソニー	SW	Si.EPa	4	4	50	140	60	0.001	3	>500	3	1			逆方向h_{FE}>500 (V_{CE}=3V, I_E=−1mA)							138D	双方向性	
★	〃 2136																									
	〃 2137	東芝	SW	Si.TMe	500	400	6 A	80W (T_c=25°C)	150	100	400	>10	5	3 A			t_r<1μs, t_f<1μs, t_{stg}<2μs							102		
★	〃 2138	〃	〃	〃	400	300	6 A	80W (T_c=25°C)	150	100	300	20	5	3 A	10	−1A	t_r<1μs, t_f<1μs, t_{stg}<2μs				6*			102		
	〃 2139	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	400	>20	5	5 A			t_r<2μs, t_f<2μs, t_{stg}<4μs							102		○
★	〃 2140	〃	〃	〃	400	300	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	300	20	5	5 A	10	−1A	t_r<2μs, t_f<2μs, t_{stg}<4μs				6*			102		
★	〃 2141	ソニー	PA	Si.EPa	140	140	500	950	120	0.2	100	150	2	100	10	−20					50*	15		174B	2SA951とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC2142	ソニー	RF	Si. E	15	15	30	165	100	0.2	15	80	10	3	10	−7					4500*	0.4	$C_c r_{bb'}$ 2.5ps	50C	
★	〃 2143	〃	Conv. Mix	Si.EPa	15	15	30	210	100	0.2	15	20~200	10	3		$\lvert S_{21e}\rvert^2$=14.5dB, NF=1 dB (10V, 3mA, 500MHz)					4500*	0.55		305B	
★	〃 2144	〃	RF	〃	15	15	30	210	100	0.2	10	30~170	10	3		h_{fe}=24dB (2.5V, 1.5mA, 100MHz) h_{fe}=11~25dB (2.5V, 5mA, 100MHz)						0.7	$C_c r_{bb'}$ 2.5ps	305A	
★	〃 2145	三菱	PA	Si. EP	35	18	2 A	10W (T_c=25°C)	175	500	25	50	10	100			P_o=3.5W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.25W)							84B	
★	〃 2146	三洋																							
★	〃 2147	サンケン	PA	Si.TMe	400	400	50A	200W (T_c=25°C)	150	1mA	400	20	4	30A	12	−1A					5*	370	12*	230	
	〃 2148	日電	RF	Si. E	30	14	50	250	200	0.1	15	80	10	10	10	−10	$\lvert S_{21e}\rvert^2$=9.3dB, NF=2.1dB (f=1GHz) (f=500MHz, I_C=3mA)				3000*	0.55		314	
	〃 2149	〃	〃	〃	25	12	70	290	200	0.1	15	70	10	20	10	−20	$\lvert S_{21e}\rvert^2$=6.7dB, NF=2.6dB (f=2GHz) (f=2GHz, I_C=5mA)				5000*	0.6		314	
★	〃 2150	〃	〃	〃	20	11	30	250	200	0.1	8	100	8	10	8	−10	$\lvert S_{21e}\rvert^2$=8.7dB, NF=2.4dF (f=2GHz) (f=2GHz, I_C=3mA)				6000*	0.35		314	
★	〃 2151	富士通	SW	Si.TMe	600	400	15A	150W (T_c=25°C)	175	100	150	20	5	7.5A										102	
★	〃 2152	松下	RF. PA	Si. EP	36	18	2 A	15W (T_c=25°C)	150	500	20	60	13.5	400	10	−300	P_o>7W, η=60% (V_{CC}=13.5V, f=500MHz, P_i=2W)				1200*	20		194	
	〃 2153	〃	RF	Si. P	30	20	20	400	150	100	30	>25	10	2	10	−2	G_{pr}>15dB, NF=2dB (V_{CC}=12V, f=200MHz)				>450*	C_{rb}<0.5		138F	フォワードAGC
★	〃 2154	〃																							
★	〃 2155	〃																							
★	〃 2156	〃																							
★	〃 2157	〃																							
★	〃 2158	〃																							
	〃 2159	サンケン	SW	Si.TMe	400	400	50A	200W (T_c=25°C)	150	100	400	15	4	30A	12	−1A	t_r<2μs, t_f<0.8μs t_{stg}<3μs				5*			230	
	〃 2160	富士通	RF. PA	Si. EP	38	18	1 A	3 W (T_c=25°C)	175	100	12	50	2	500	12	−100	P_o=1.3W (V_{CC}=12.5V, f=470MHz, P_i=0.3W)				1200*	5		54B	
	〃 2161	〃	〃	〃	38	18	1 A	7 W (T_c=25°C)	175	100	12	50	2	500	12	−100	P_o=2.5W (V_{CC}=12.5V, f=470MHz, P_i=0.3W)				1200*	5		330	
	〃 2162	〃	〃	〃	38	18	2 A	12W (T_c=25°C)	175	200	12	50	2	1 A	12	−200	P_o=5W (V_{CC}=12.5V, f=470MHz, P_i=1W)				1000*	10		330	
	〃 2163	〃	〃	〃	45	25	5 A	30W (T_c=25°C)	175	500	12	50	2	2 A	12	−500	P_o=15W (V_{CC}=12.5V, f=470MHz, P_i=5W)				800*	38		330	
	〃 2164	〃	〃	〃	45	25	10A	50W (T_c=25°C)	175	1mA	12	50	2	3 A	12	−1A	P_o=30W (V_{CC}=12.5V, f=470MHz, P_i=10W)				700*	75		331	
	〃 2165	日立	SW	Si.EPa	120	120	5 A	800	175	100	100	>1000	5	5 A			t_{on}=0.4μs, t_{off}=4 μs							85B	ダーリントン(増幅素子)ダンパ内蔵
	〃 2166	三菱	PA	Si. EP	75	75R	4 A	12.5W (T_c=25°C)	150	100	30	70	10	100			P_o=7.5W, η=60% (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.25W)							301B	
	〃 2167	サンケン	〃	Si.TMe	150	150	2 A	30W (T_c=25°C)	150	100	150	100	10	700	12	−200					15*	20	35	298	2SA957とコンプリ
	〃 2168	〃	〃	〃	200	200	2 A	30W (T_c=25°C)	150	100	200	100	10	700	12	−200					15*	20	35	298	2SA958とコンプリ
	〃 2169	富士通	〃	Si. EP	36	33	4 A	25W (T_c=25°C)	175	300	12	50	2	1.5A	12	−300					1500*	15	30*	257	
★	〃 2170	〃																							
★	〃 2171	〃																							

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SC2172	日電	AF	Si. E	60	45	200	150	125	0.1	45	80	1	50										176	
	〃 2173	東芝	PA	Si. EP	35	18	6 A	40W (Tc=25°C)	175	1mA	15	>10	5	1 A			P_o=28W (f=470MHz, V_{CE}=12.6V, P_i=12W)					<80		316	
	〃 2174	日電	RF	Si. E	25	12	70	350	200	0.1	15	70	10	20	10	−10	$\|S_{21e}\|^2$=6.5dB (10V, 20mA, 2GHz) NF=2.7dB (10V, 5mA, 2GHz)				4500*	0.6		339	
★	〃 2175	三菱	SW	Si. T	350	350	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	350	>15	5	5 A			t_{on}<0.25μs, t_f<0.35μs t_{stg}<2.5μs							102	
★	〃 2176	東芝	PA	Si. EP	50	25	3 A	30W (Tc=25°C)	175	100	20	>10	5	1 A	10	−300	P_o=12W (f=270MHz, V_{CE}=20V, P_i=1W)				>200*	<40		316	
★	〃 2177	〃	〃	〃	50	25	5 A	45W (Tc=25°C)	175	200	20	>10	5	1 A	10	−400	P_o=22W (f=270MHz, V_{CE}=20V, P_i=4W)				>200*	50		316	
	〃 2178	〃	〃	〃	35	18	3.5A	35W (Tc=25°C)	175	1mA	15	>10	5	1 A			P_o=17W (f=175MHz, V_{CE}=12.5V, P_i=1.3W)					<80		325	
★	〃 2179	富士通	RF. PA	〃	55	40	6 A	65W (Tc=25°C)	175	1.2mA	20	50	5	5 A			P_o=40W (V_{CC}=24V, f=770MHz, P_i=15W)					45		40	
★	〃 2180	東芝	PA	〃	35	18	6 A	40W (Tc=25°C)	175	1mA	15	50	5	1 A			P_o=27W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=5W)							316	
	〃 2181	〃	〃	〃	35	18	10A	70W (Tc=25°C)	175	2mA	15	>10	5	2 A	10	−400	P_o=43W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=10W)				300*	<160		325	
	〃 2182	〃	〃	〃	65	35	6 A	60W (Tc=25°C)	175	1mA	30	>10	5	1 A	10	−200	P_o=50W (f=175MHz, V_{CE}=28V, P_i=10W)				150*	<100		316	
★	〃 2183	〃	〃	〃	35	18	4.5A	30W (Tc=25°C)	175	100	15	40	5	1.5A	10	−200	P_o=16W (f=470MHz, V_{CE}=12.6V, P_i=6W)				400*	40		316	
★	〃 2184	富士通	RF. PA	〃	60	60	3 A	10W (Tc=25°C)	150	10	30	100	5	100	5	−100	P_o=5W (V_{CC}=12V, f=27MHz, P_i=0.1W)				200*	30		268	
	〃 2185	日電	PA	Si. E	50	25	6 A	75W (Tc=25°C)	200	1 mA	30	60	10	2 A			P_o=30W (f=275MHz, V_{CC}=18V, P_i=3 W)							233	
	〃 2186	〃	〃	〃	50	25	9 A	110W (Tc=25°C)	200	4.5mA	30	60	10	3 A			P_o=60W (f=275MHz, V_{CC}=18V, P_i=10W)							233	
	〃 2187																								
	〃 2188	松下	RF. PA	Si. EP	45	35	50	600	135	0.1	20	50	10	10	10	−10	G_{pe}>18dB (f=58MHz)				500*	1.5	20	151	
	〃 2189	富士電機	SW	Si. TP	150	100	10A	80W (Tc=25°C)	150	100	150	>40	5	4 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							102	
	〃 2190	〃	〃	〃	450	400	5 A	100W (Tc=25°C)	150	100	450	>15	5	2 A			t_{on}<1.5μs, t_f<1.3μs t_{stg}<4μs							102	
	〃 2191	〃	〃	〃	450	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	450	>15	5	4 A			t_{on}<2μs, t_f<1.2μs t_{stg}<4μs							102	
★	〃 2192	松下	RF. PA	Si. EP	36		I_{CM} 5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	20	50	10	400	10	−300	P_o>15W, η=70% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=2.5W)				600*	35		194	
	〃 2193	沖	RF	Si. E	150	120	300	600	175	1	120	70	5	50	10	−30					150*	4	20*	84B	
★	〃 2194	東芝	PA	Si. T	60	50	1.5A	1 W	150	1	50	120	2	150	10	−100					100*	20	50	249	
★	〃 2195	日電																							
	〃 2196	富士通	RF. PA	Si. EP	40	18	2 A	7 W (Tc=25°C)	175	200	12	50	2	1 A	10	−100	P_o=4.8W (V_{CC}=12.5V, f=175MHz, P_i=0.25W)				800*	10		54B	
	〃 2197	〃	〃	〃	50	25	6 A	60W (Tc=25°C)	175	2mA	12	50	2	3 A	12	−500	P_o=30W (V_{CC}=13.5V, f=160MHz, P_i=3W)				500*	100		330	
★	〃 2198	サンケン	PA	Si. EMe	100	50	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	>300	4	1 A	10	−500					15*			99	
★	〃 2199	〃	PA. SW	〃	150	80	8 A	60W (Tc=25°C)	150	100	150	600	4	1 A	12	−500	t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs				15*	100	30	102	
	〃 2200	東芝	SW	Si. TMe	500	400	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	400	>10	5	3 A			t_r<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2 μs							134	
★	〃 2201	〃																							

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SC2202	富士通																								
★	〃 2203	〃																								
	〃 2204	東芝	SW	Si.TMe	800	400	30A	250W (Tc=25°C)	150	1mA	800	>10	5	30A			t_{on}<1.5μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs					400		266		
	〃 2205	日電	Diff.	Si. E	45	25	30	200/unit.	200	0.05	30	100	6	6	5	−20	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8～1.0 ΔV_{BE}<30mV				2200*	1.3	130*	310	2素子複合	
	〃 2206	松下	RF	Si.EP	30	20	30	400	150	0.1	10	100	10	1	10	−1	NF=2.8dB (f=5MHz)				300*	1.3	22	151		
★	〃 2207	日立	PA	Si. E	80	50	8A	25W (Tc=25°C)	150	100	60	30～150	10	2A			P_O=14W, η>60% (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=1W)							268		
	〃 2208	〃	SW	Si.EPa	120	120	5A	800	175	100	120	>1000	5	5A			t_{on}=0.4μs, t_{off}=4μs							84B	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 2209	松下	PA	Si.EP	50	40	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	1	20	120	5	1A	5	−500					150*	50		236	2SA963とコンプリ	
	〃 2210	三洋	RF. Conv	〃	30	20	30	250	125	0.1	10	40～320	6	1	6	−1	NF=2.0dB (10V, 0.5mA, 455kHz)				90*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 25ps	138		
★	〃 2211	ソニー																								
★	〃 2212	〃	RF	Si. E	15	15	20	250	100	I_{CES} 0.2	10	30～170	10	3			h_{FE}=24dB (10V, 3mA, f=100MHz)					0.8	$C_c r_{bb'}$ 4ps	138D		
★	〃 2213	〃	Osc.	Si.EPa	30	15	50	250	100	I_{CES} 0.2	15	70	10	5			h_{fe}=24dB (10V, 5mA, 100MHz)					1.1	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138D		
★	〃 2214	〃	PA. SW	〃	100	80	4A	10W (Tc=25°C)	175	0.5	50	100	2	100			t_d=45ns, t_{stg}=550ns t_r=30ns, t_f=60ns				140*	45	$C_c r_{bb'}$ 35ps	181		
	〃 2215	東芝	RF	Si. P	40	40	50	250	125	0.1	40	>30	10	4	10	−4	G_{pe}=32～40dB (V_{CE}=12V, I_C=4mA, f=45MHz)				>400*	C_{re} <1.2pF	$C_c r_{bb'}$ <30ps	138C	フォワードAGC	
	〃 2216	〃	〃	Si.EP	50	45	50	300	125	0.1	50	40～140	12.5	12.5	12.5	−12.5	G_{pe}=29～36dB (V_{CE}=12.5V, I_C=12.5mA, f=45MHz)				>300*	0.8～2.0	$C_c r_{bb'}$ <25ps	138C		
	〃 2217	日電	RF. LN	Si. E	20	12	80	580	200	1	8	100	8	20	8	−20	$\|S_{21e}\|^2$=9.6dB (8V, 20mA, 2GHz)				8000*	C_{re} 0.4		190		
	〃 2218	〃	〃	〃	20	12	80	350	200	1	8	100	8	20	8	−20	$\|S_{21e}\|^2$=9.6dB (8V, 20mA, 2GHz)				8000*	C_{re} 0.4		320		
★	〃 2219	〃	〃	〃	20	12	80	700 (Tc=151°C)	200	1	8	100	8	20	8	−20	$\|S_{21e}\|^2$=9.6dB (8V, 20mA, 2GHz)				8000*	C_{re} 0.4		311		
★	〃 2220	東芝	SW	Si.TMe	500	300	30A	250W (Tc=25°C)	150	1mA	500	>10	5	30A			t_{on}<1.5μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs					400		266		
	〃 2221	日電	RF. PA	Si. E	25	12	750	7.5W (Tc=25°C)	175	250	20	60	7	200			P_O=33dBm, η=70% (V_{CC}=7.2V, f=175MHz, P_i=23dBm)					C_{re} 7		84C		
	〃 2222	〃	〃	〃	25	12	1.5A	17W (Tc=25°C)	175	500	20	60	7	400			P_O=38dBm, η=70% (V_{CC}=7.2V, f=175MHz, P_i=28.5dBm)					C_{re} 12		129		
	〃 2223	〃	RF. LN	〃	30	20	20	150	125	0.1	25	90	6	1	6	−1	NF=3dB (6V, 1mA, 100MHz)				600*	1	$C_c r_{bb'}$ 12ps	176		
★	〃 2224	〃	PA	Si.EP	200	200	200	10W (Tc=25°C)	150	1	180	180	10	10	10	−10					100*	2	23*	167C		○
★	〃 2225	〃																								
★	〃 2226	〃																								
★	〃 2227	〃	RF	Si. E	35	18	200	7W (Tc=25°C)	200	10	20	60	15	100	10	−60	$\|S_{21e}\|^2$=8dB (0.5GHz) NF=4dB (1GHz)				2400*			85B		
	〃 2228	三洋	〃	Si.TP	160	160	50	750	125	1	160	40～320	10	10	30	−10					>50*	<7.5		294		○
	〃 2229	東芝	AF. PA. SW	Si. T	200	150	50	800	150	0.1	200	70～240	5	10	30	−10					120*	3.5	25	241	2SA949とコンプリ	
	〃 2230	〃	AF. RF	〃	200	160	100	800	150	0.1	200	120～400	10	10	10	−10					>50*	<7	30	241		○
	〃 2231	〃	〃	〃	200	160	200	1.5W	150	0.1	200	100～320	10	50	10	−50					>50*	<10	50	178		○

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC2232	日電																								
	〃 2233	東芝	PA	Si.T	200	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	170	30~150	5	1 A	5	−500					8 *	80	50	268		
★	〃 2234	〃	〃	Si.EP	35	18	10A	70W (Tc=25°C)	150	2mA	15	>10	5	5 A	10	−400	P_o>40W, η>60% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=10W)				300 *	<160		316		
	〃 2235	〃	〃	Si.E	120	120	800	900	150	0.1	120	80~240	5	100	5	−100					120 *	<30		241	2SA965 とコンプリ	
	〃 2236	〃	〃	〃	30	30	1.5A	900	150	0.1	30	100~320	2	500	2	−500					120 *	<30		241	2SA966 とコンプリ	
	〃 2237	三菱	〃	Si.EP	35	17	2 A	20W (Tc=25°C)	175	500	25	50	10	100			P_o=7.5W, η=65% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.25W)							272A		
	〃 2238	東芝	RF.PA	Si.E	160	160	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	1	160	70~240	5	100	10	−100					100 *	25	4 *	268	2SA968 とコンプリ	○
★	〃 2239	〃	〃	〃	160	160	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	1	160	70~240	5	100	10	−100					100 *	25	4 *	99	2SA969 とコンプリ	
	〃 2240	〃	AF.LN	〃	120	120	100	300	125	0.1	120	200~700	6	2	6	−1	NF<6dB (f=10Hz, 6V, 0.1mA)		NF<2dB (f=1kHz)		100 *	3		138	2SA970 とコンプリ	
★	〃 2241	〃	PA	Si.T	300	300	150	20W (Tc=25°C)	150	1	240	40~170	10	50	10	−30					>50 *	3.8	15	268		
	〃 2242	〃	〃	〃	300	300	150	25W (Tc=25°C)	150	1	240	40~170	10	50	50	−20					50 *	5.5		268		
	〃 2243	富士電機	SW	Si.TP	450	400	5 A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	2 A			t_{on}<1μs, t_f=1μs t_{stg}<2μs							102		
	〃 2244	〃	〃	〃	450	400	8 A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	3 A			t_{on}<1μs, t_f=1μs t_{stg}<2μs							102		
	〃 2245	〃	〃	〃	450	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	4 A			t_{on}<1μs, t_f=1μs t_{stg}<2μs							102		
	〃 2246	〃	〃	〃	450	400	15A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	6 A			t_{on}<1μs, t_f=1μs t_{stg}<2μs							102		
	〃 2247	〃	〃	〃	450	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	2 A			t_{on}<1μs, t_f=1μs t_{stg}<2μs							321		
	〃 2248	〃	〃	〃	450	400	8 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	3 A			t_{on}<1μs, t_f=1μs t_{stg}<2μs							321		
	〃 2249	〃	〃	〃	250	200	30A	200W (Tc=25°C)	150	1 mA	250	>10	5	15A			t_{on}<2μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs							266		
	〃 2250	〃	〃	〃	450	400	30A	200W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	15A			t_{on}<2μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs							266		
	〃 2251	富士通	PA	Si.EP	45	29	500	7 W (Tc=25°C)	175	100	20	50	5	200			P_o=1.8W (f=900MHz, V_{CE}=18V, P_i=0.5W)							159		
★	〃 2252	〃 〃	〃	〃	45	29	1 A	12W (Tc=25°C)	175	200	20	50	5	500			P_o=4.5W (f=900MHz, V_{CE}=18V, P_i=1.5W)							159		
	〃 2253	〃	〃	〃	45	29	2 A	25W (Tc=25°C)	175	400	20	50	5	1 A			P_o=9 W (f=900MHz, V_{CE}=18V, P_i=4 W)							159		
	〃 2254	〃	〃	〃	45	29	4 A	40W (Tc=25°C)	175	800	20	50	5	3 A			P_o=12W (f=900MHz, V_{CE}=18V, P_i=6 W)							159		
	〃 2255	〃	〃	〃	45	29	6 A	65W (Tc=25°C)	175	1.2mA	20	50	5	5 A			P_o=22W (f=900MHz, V_{CE}=18V, P_i=10W)							329		
★	〃 2256	サンケン	〃	Si.TMe	200	150	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	200	60	4	5 A	12	−500					10 *	110	18 *	102		
★	〃 2257	松下	〃	Si.EP	180	180	50	1 W	150	1	100	170	5	10	10	−10					80 *	2	70	222		○
	〃 2258	〃	AF.RF	Si.TP	250	250	100	1 W	150	100	250	>40	20	40	10	−10					100 *	3		222		○
	〃 2259	三菱	LN.Diff	Si.EP	100	100	50	200/unit	125	0.1	70	250~1200	6	1	6	−1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0				100 *	1.8		274B	2本イッポウ 2SA979 とコンプリ	
★	〃 2260	サンケン	PA	Si.TMe	160	100	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	100	>30	4	3 A	12	−500					15 *			102	2SA980 とコンプリ	
★	〃 2261	〃	〃	〃	180	120	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	120	>30	4	3 A	12	−500					15 *			102	2SA981 とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC2262	サンケン	PA	Si.TMe	200	140	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	140	>30	4	3 A	12	−500					15 *			102	2SA982 とコンプリ
★	〃 2263	松下	RF	Si.EP	60	55	50	250	125	0.1	30	500	5	2	10	−1					70 *	15		138	
	〃 2264	〃	AF.PA	〃	90	20	1 A	750	135	0.1	20	100~350	0.5	1 A	10	−50					200 *	<20		294	
★	〃 2265	日立	RF	Si.P	35	35	20	150	175	0.1	10	30~150	10	2	10	−2					550 *	<0.6		50C	
★	〃 2266	〃	SW	Si.T	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	30	5	5 A			t_{on}<1.5μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							102	
	〃 2267	〃	〃	〃	400	360	100	400	150	1	250	35~200	20	20	10	−10					70 *	4		49C	2SA1024 とコンプリ
★	〃 2268	東芝																							
★	〃 2269	〃																							
★	〃 2270	〃	SW.PA	Si.E	50	20	5 A	10W (Tc=25°C)	150	0.1	40	140~450	2	500	2	−500					100 *	40		342	2SA1120 とコンプリ
	〃 2271	三洋	RF	Si.TP	300	300	100	900	150	1	200	40~200	10	10	30	−10					>50*	<7.5		294	
	〃 2272	日電	RF.LN	Si.E	20	10	35	250 (Ta=100°C)	200	0.1	8	50~250	6	5	6	−5	$\|S_{21e}\|^2$=8.5dB (6V, 5mA, 4GHz)				10000*	Cre 0.2		320	
	〃 2273	〃	〃	〃	25	12	65	400 (Ta=40°C)	200	0.1	8	50~250	8	7	8	−7	G_{pe}=12dB (8V, 7mA, 2GHz)				8500*	Cre 0.2		320	
	〃 2274	三洋	AF	Si.EP	60	50	500	600	150	1	40	60~320	5	50	10	−10					120 *	5		138	2SA984 とコンプリ
	〃 2275	日電	PA	Si.E	120	120	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	1	120	150	5	300	5	−200					200 *	19		268	2SA985 とコンプリ ○
★	〃 2276	〃	〃	〃	130	130	7 A	80W (Tc=25°C)	150	50	120	150	5	1 A	5	−1A					100 *	150	15	295	
	〃 2277	日立	RF	〃	50	50	500	625	150	0.1	50	60~320	3	150	3	−10					120 *	7		138D	2SA993 とコンプリ
	〃 2278	〃	〃	Si.T	300	300	100	1.25W	150	I_{CEO} 1	V_{CE} 250	30~200	20	20	20	−20					80 *	Cre 2		234C	
★	〃 2279	東芝	RF.PA	〃	300	300	100	10W (Tc=25°C)	150	0.1	300	30~150	10	20	10	−20					35 *	3		177	
★	〃 2280	日電		〃																					
	〃 2281	〃	RF.PA	Si.E	38	18	1.5A	17W (Tc=25°C)	175	500	30	60	10	400			P_o=39.2dBm, η=65% (V_{cc}=13.5V, f=175MHz, P_i=26dBm)					Cre 12		129	
	〃 2282	〃	〃	〃	38	18	3 A	34W (Tc=25°C)	175	1mA	30	60	10	800			P_o=43dBm, η=65% (V_{cc}=13.5V, f=175MHz, P_i=34dBm)					Cre 25		43	
	〃 2283	〃	〃	〃	38	18	750	10W (Tc=25°C)	175	250	30	60	10	200			P_o=35.5dBm, η=60% (V_{cc}=12.6V, f=500MHz, P_i=25dBm)					Cre 6		326	
	〃 2284	〃	〃	〃	38	18	1.5A	17W (Tc=25°C)	175	500	30	60	10	400			P_o=39.5dBm, η=65% (V_{cc}=12.6V, f=500MHz, P_i=33dm)					Cre 12		326	○
	〃 2285	〃	〃	〃	38	18	3 A	34W (Tc=25°C)	175	1mA	30	60	10	800			P_o=42.3dBm, η=60% (V_{cc}=12.6V, f=500MHz, P_i=38dBm)					Cre 25		326	○
	〃 2286	〃	PA	〃	38	18	750	10W (Tc=25°C)	200	250	30	60	10	200			P_o=35dBm, η=60% (V_{cc}=13.5V, f=175MHz, P_i=18dBm)					6		326	
	〃 2287	〃	RF.PA	〃	38	18	1.5A	17W (Tc=25°C)	175	500	30	60	10	400			P_o=39.5dBm, η=65% (V_{cc}=13.5V, f=175MHz, P_i=26dBm)					Cre 12		326	
	〃 2288	〃	〃	〃	38	18	3 A	34W (Tc=25°C)	175	1mA	30	60	10	800			P_o=43dBm, η=65% (V_{cc}=13.5V, f=175MHz, P_i=34dBm)					Cre 25		326	
	〃 2289	〃	〃	〃	25	12	1.5A	17W (Tc=25°C)	175	500	20	60	7	400			P_o=38.5dBm, η=70% (V_{cc}=7.2V, f=175MHz, P_i=28.5dBm)					Cre 12		326	
	〃 2290	東芝	PA	Si.EP	45	18	20A	175W (Tc=25°C)	175			10~150	5	10A			P_o=60W (PEP) (f=28MHz, V_{cc}=12.5V, P_i=2.5W)					<500		281	
	〃 2291	三菱	定電流回路 能動負荷	〃	100	100	100	200/unit	125	0.1	100	250~1200	6	1	6	−1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.25				100 *	2.5		274D	2素子複合

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)		直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC2292	新電元	SW	Si. T	500	400	8 A	80W (T_c=25°C)	150	100	500	20	2	4 A	10	−1 A	t_{on}<1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}<3 μs				20 *			102	T8M40F1
	〃 2293	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	500	20	2	5 A	10	−1 A	t_{on}<1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}<3 μs				20 *			102	T10M40F1
	〃 2294	松下	RF	Si.EP	30	20	30	250	125	1	10	100	10	1	10	−1					200 *	2	20	138	
	〃 2295	〃	〃	〃	30	20	30	200	125	0.1	10	50~220	10	1	10	−1	NF=2.8dB (100MHz, 10V, 1mA)				>150 *	C_{re} 0.9	Z_{rb} 22	176	2SA1022とコンプリ
★	〃 2296	三菱	〃	〃	30	30	30	200	125	1	25	90	6	1	6	−1					230 *	2	$C_c r_{bb'}$ 25ps	138	
★	〃 2297	日立	PA	Si. E	55	55R	8 A	25W (T_c=25°C)	150	0.1	45	100	10	2 A	10	−150	P_o>16W, η>60% (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=1W)				130 *	140	0.4	268	
	〃 2298	〃	RF	〃	30	30	1 A	8 W (T_c=25°C)	150	10	30	>4000	3	400										160	ダーリントン
★	〃 2299	富士通	〃	Si. EP	20	20	1 A	500	150	0.5	15	200	5	10	5	−10					150 *	10	15 *	138	
★	〃 2300	〃	〃	〃	50	50	1 A	500	150	0.5	40	200	5	10	5	−10					150 *	10	15 *	138	
	〃 2301	日電	PA	Si. E	45	45R	2.8A	46W (T_c=25°C)	200	2 mA	30	30	10	2 A			P_o=16W (f=890MHz, V_{CC}=18V, P_i=3.6W)							164	
★	〃 2302	サンケン	SW	Si. T	500	400	7 A	40W (T_c=25°C)	150	100	500	15	4	5 A			t_{on}<1.3μs, t_f<1.2μs t_{stg}<3.5μs							100	
★	〃 2303	〃	〃	〃	500	400	7 A	80W (T_c=25°C)	150	100	500	15	4	5 A			t_{on}<1.3μs, t_f<1.2μs t_{stg}<3.5μs							102	
★	〃 2304	〃	〃	〃	500	400	12A	100W (T_c=25°C)	150	100	500	15	4	10A			t_{on}<1.3μs, t_f<1.2μs t_{stg}<3.5μs							102	
★	〃 2305	〃	〃	〃	400	400	7 A	80W (T_c=25°C)	150	100	400	>10	4	5 A										324	
★	〃 2306	サンケン	SW	Si.TMe	450	400	15A	150W (T_c=25°C)	150	1mA	450	>10	4	5 A	12	−500	t_r=0.35μs, t_f=0.35μs t_{stg}=2.1μs				7 *			102	
	〃 2307	〃	〃	Si. TP	500	400	12A	100W (T_c=25°C)	150	100	500	15	4	7 A			t_{on}<0.7μs, t_f<0.7μs t_{stg}<2.5μs							324	
	〃 2308	日立	AF	Si. E	55	50	100	200	150	0.5	18	100~320	12	2	12	−2					230 *	1.8		138	2SA1030とコンプリ
	〃 2309	〃	〃	〃	55	50	100	200	150	0.5	18	250~1200	12	2	12	−2					230 *	1.8		138	
	〃 2310	〃	LN	〃	55	50	100	200	150	0.5	18	100~320	12	2	12	−2	NF= 3 dB (6V, 0.1mA, 120Hz)				230 *	1.8		138	2SA1032とコンプリ
	〃 2311	富士通	SW	Si. EP	50	40	1 A	1 W	150	0.5	40	55	1	500			t_{on}=45nS, t_{off}=90nS t_{stg}=70nS					<12		328	
	〃 2312	三菱	PA	〃	60	20	6 A	25W (T_c=25°C)	150	500	30	50	10	100			P_o=18.5W (V_{CC}=12V, f=27MHz, P_i=1.5W)							301B	
	〃 2313	〃	〃	〃	40	17	10A	60W (T_c=25°C)	175	1mA	25	50	10	1 A			P_o=38W (f=65MHz, V_{CE}=12V, P_i=3.5W)							323	
	〃 2314	三洋	RF.PA	〃	75	45	1 A	5 W (T_c=25°C)	150	1	40	60~320	5	500	10	−50	P_o=1.8W, η>60% (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=35mW)				250 *	15		296	
	〃 2315	サンケン	PA	Si.TMe	80	60	6 A	50W (T_c=25°C)	150	100	80	800	4	500	12	−500					30 *	140	20	298	
	〃 2316	〃	〃	〃	100	80	6 A	50W (T_c=25°C)	150	100	100	800	4	500	12	−500					30 *	140	20	298	
★	〃 2317	〃	〃	〃	200	150	1 A	30W (T_c=25°C)	150	100	200	1000	4	200	12	−100					30 *	45	45	298	
	〃 2318	東芝	〃	Si.EP	40	15	350	3.5W (T_c=25°C)	175	1	30	30~180	5	100	10	−90	G_{pe}=16dB (10V, 90mA, 250MHz)				2700 *	2.9		85B	
	〃 2319	〃	〃	〃	40	15	350	5 W (T_c=25°C)	175	1	30	30~180	5	100	10	−90	G_{pe}=16dB (10V, 90mA, 250MHz)				2900 *	3.5		270	
	〃 2320	三菱	AF	Si. E	50	50	200	300	125	0.1	50	90~800	6	1	6	−10	NF<15dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				200 *	2.5		138	2SA999とコンプリ
★	〃 2321	富士通	RF. AF	Si. EP	130	130	8 A	80W (T_c=25°C)	150	50	130	100	5	500	10	−1A					60 *	250		102	2SA1001とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC2322	富士通	RF.AF	Si.EP	120	120	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	120	100	5	500	10	−1A					60 *	300		102	2SA1002とコンプリ	
★	〃 2323	〃	〃	〃	150	150	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	150	100	5	500	10	−1A					60 *	300		102	2SA1003とコンプリ	
	〃 2324	日立	PA	Si.E	60	60	1A	8W (Tc=25°C)	150	10	60	>2000	10	500			t_{on}=100ns, t_{off}=600ns							160	ダーリントン	
★	〃 2325	日電	〃	〃	45	45R	600	10.9W (Tc=25°C)	200	250	30	30	3	600			P_o=1.32W (V_{CC}=20V, f=4.2GHz, P_i=0.32W)							352		
★	〃 2326	〃	〃	〃	45	45R	1.2A	17.5W (Tc=25°C)	200	500	30	30	3	1.2A			P_o=2.8W (V_{CC}=20V, f=4.2GHz, P_i=0.8W)							352		
★	〃 2327	東芝																								
★	〃 2328	〃																								
	〃 2329	日電	RF.PA	Si.E	38	18	750	7.5W (Tc=25°C)	175	250	30	60	10	200			P_o=34dBm, η=70% (V_{CC}=13.5V, f=175MHz, P_i=20dBm)					C_{re} 7		84C		
★	〃 2330	〃	〃	〃	38	18	6A	70W (Tc=25°C)	175	2mA	30	60	10	1A			P_o=45.7dBm, η=75% (V_{CC}=13.5V, f=175MHz, P_i=39dBm)					C_{re} 55		327		
	〃 2331	〃	SW	〃	150	100	2A	15W (Tc=25°C)	150	10	100	40~200	5	1A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							268	2SA1008とコンプリ	
★	〃 2332	〃																								
	〃 2333	〃	SW	Si.T	500	400	2A	15W (Tc=25°C)	150	10	400	20~80	5	1A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							268		
	〃 2334	〃	〃	Si.E	150	100	7A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	40~200	5	3A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							268	2SA1010とコンプリ	
	〃 2335	〃	〃	Si.T	500	400	7A	40W (Tc=25°C)	150	10	400	20~80	5	1A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							268		
	〃 2336	〃	PA	Si.E	180	180	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	1	150	120	5	150	10	−100					95 *	30	14 *	268		○
★	〃 2337	〃	〃	〃	150	130	10A	100W (Tc=25°C)	150	50	150	150	5	1A	5	−200	t_{on}=0.2μs, t_{off}=1.8μs t_{stg}=1.5μs				70 *	150		102	2SA1007とコンプリ	○
	〃 2338	〃	RF.Osc	〃	25	12	60	600 (Tc=25°C)	200	1	10	100	10	30	10	−30	$\|S_{21e}\|^2$= 6dB (10V, 30mA, 4GHz)				10000*	0.18		320		
	〃 2339	〃	〃	〃	25	15	200	4W (Tc=25°C)	200	5	10	60	10	80	10	−80	$\|S_{21e}\|^2$=6.5dB (10V, 80mA, 2GHz)				6500*	0.55		207		
	〃 2340	〃	PA	〃	30	20	300	6W (Tc=25°C)	200	5	10	100	10	130	14	−130	P_o=28dBm (f=2GHz, P_i=168dBm)				6500*	0.9		118A		
	〃 2341	〃	RF.Osc	〃	25	12	60	600 (Tc=25°C)	200	1	10	100	10	30	10	−30	P_{osc}=21dBm (10V, 40mA, 7.5GHz)				10000*	0.18		311		
	〃 2342	〃	〃	〃	25	15	200	4W (Tc=25°C)	200	5	10	60	10	80	10	−80	P_{osc}=22dBm (10V, 80mA, 6GHz)				6500*	0.55		311		
	〃 2343																									
★	〃 2344	三洋	PA	Si.EP	180	160	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	10	120	60~200	5	300	10	−50					100 *	23		268	2SA1011とコンプリ	
★	〃 2345	東芝	RF	Si.P	25	20	20	150	125	0.1	10	100	10	2	10	−2	G_{pb}=17dB, NF=3.5dB (V_{CC}=12V, f=800MHz)				900 *	C_{rb} 0.25		343	フォワードAGC	
★	〃 2346	〃																								
	〃 2347	〃	Mix	Si.EP	30	15	50	250	125	0.1	15	>20	3	8	10	−8					>650*	1.2	$C_c r_{bb'}$ <12ps	138		
	〃 2348	〃	RF.LN	Si.P	30	30	20	250	125	0.1	25	40~200	10	2	10	−2	G_{pe}=24dB, NF=2.3dB (V_{CE}=11V, I_C=2mA, f=200MHz)				650 *	C_{re} 0.3	$C_c r_{bb'}$ 11.5ps	138C	フォワードAGC	
	〃 2349	〃	Osc	Si.EP	30	15	50	250	125	0.1	15	>20	3	8	10	−8					>600*	1.2	$C_c r_{bb'}$ <20ps	138		
★	〃 2350	日電	RF	Si.E	30	14	50	250	150	0.1	15	100	10	10	10	−10	$\|S_{21e}\|^2$=8.5dB (1GHz) NF=2.3dB (10V, 3mA, 0.5GHz)				2800*			176		
	〃 2351	〃	〃	〃	25	12	70	250	150	0.1	15	40~200	10	20	10	−20	$\|S_{21e}\|^2$=10dB (1GHz) NF=1.5dB (10V, 5mA, 1GHz)				4500*	C_{re} 0.75		176		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC2352	日電	Mix	Si. E	30	20	30	250	125	0.1	20	100	10	5	10	−5	G_{ce}=23dB (10V, 3mA, 200MHz)				850*	C_{rc} 0.37		138C	
	〃 2353	〃	〃	〃	30	14	50	200	125	0.1	15	100	10	5	10	−5	G_{cb}=12.5dB (10V, 5mA, 900MHz)				2300*	0.85		210A	
★	〃 2354	サンケン	PA	Si.TMe	300	250	1 A	30W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	100	4	200	12	−100					10*	18	20	99	
★	〃 2355	東芝																							
	〃 2356	富士通	SW. PA	Si.TMe	500	400	10A	100W (T_c=25°C)	175	100	500	20	5	5 A			t_r=1μs, t_f=0.7μs t_{stg}=1.6μs							102	
★	〃 2357	〃	〃	〃	1000	700	10A	150W (T_c=25°C)	175	100	1000	15	5	5 A			t_r=1.5μs, t_f=0.8μs t_{stg}=2.5μs							102	
★	〃 2358	〃	〃	〃	1000	800	10A	150W (T_c=25°C)	175	100	1000	15	5	5 A			t_r=1.5μs, t_f=0.8μs t_{stg}=2.5μs							102	
	〃 2359	〃	〃	〃	450	400	4 A	40W (T_c=25°C)	175	100	450	20	5	2 A			t_r=0.3μs, t_f=0.45μs t_{stg}=1.3μs							99	
★	〃 2360	松下	RF	Si. P	30	20	20	200	135	1	25	>20	10	3	10	−3	G_{pe}=16dB, NF= 4 dB (f=800MHz)				1100*	0.7		337A	フォワードAGC
★	〃 2361	〃	PA	Si.EP	70	40	4 A	25W (T_c=25°C)	150	10	20	50~240	3	2.5A	10	−200					70*			268	
	〃 2362	三洋	AF. LN	〃	120	100	50	400	125	1	80	160~960	6	1	6	−1	V_{NO}<35mV (30V, 1mA, R_G=56kΩ, A_v=77dB)				130*	1.8		138	2SA1016とコンプリ
	〃 2363	〃	AF	〃	120	100	50	500	125	1	80	100~560	6	1	6	−1					130*	1.8		138	2SA1017とコンプリ
★	〃 2364	サンケン	PA	Si. TMe	200	150	5 A	80W (T_c=25°C)	150	100	200	1000	4	1 A	12	−500					15*	130	20	324	
★	〃 2365	〃	〃	〃	600	500	6 A	50W (T_c=25°C)	150	100	600	12	4	3 A	12	−500					10*	55	3.5	102	
	〃 2366	富士通	SW. PA	〃	500	400	40A	300W (T_c=25°C)	175	100	500	20	5	20A			t_r=1μs, t_f=1μs t_{stg}=2μs							41	
	〃 2367	日電	RF. LN	Si. E	20	10	80	580	200	1	8	50~300	8	20	8	−20	$\|S_{21e}\|^2$= 9 dB (8 V, 20mA, 2 GHz)				8000*	C_{rc} 0.4		314	
★	〃 2368	〃	RF	〃	30	14	50	250	150	0.1	15	40~200	10	10	10	−10	$\|S_{21e}\|^2$ =14.5dB (10V, 10mA, 500MHz)				2800*	0.7		210B	
★	〃 2369	〃	〃	〃	25	12	70	250	150	0.1	15	70	10	20	10	−20	G_{pe}=14dB, NF=1.8dB (f=1GHz) (f=1GHz, I_c=5mA)				4500*	0.75		210B	
	〃 2370	東芝	PA	〃	35	17	800	7.5W (T_c=25°C)	175	500	15	50	5	500			P_o= 4 W (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=0.4W)							208	
	〃 2371	日電	RF	Si. T	300	300	100	10W (T_c=25°C)	150	0.1	200	40~250	10	10	30	−10					80*	C_{rc} <3		225	
	〃 2372																								
★	〃 2373	日電	PA	Si. E	200	100	7.5A	40W (T_c=25°C)	150	10	150	35	5	5 A	5	−100	t_f< 1 μs				10*			268	
★	〃 2374	〃																							
★	〃 2375	三洋	AF	Si.EP	150	120	50	900	150	1	80	100~560	6	1	6	−1					130*	1.8		294	2SA1019とコンプリ
★	〃 2376	東芝	PA	Si. T	300	300	150	20W (T_c=25°C)	150	1	240	80	10	50	50	−20					50*	6	50	342	
	〃 2377	松下	RF	Si.EP	30	20	15	400	150	0.1	10	150	6	1	6	−1					650*	1.2	70	151	
	〃 2378	日電	AF	Si. E	70	70	100	250	125	0.1	70	200	6	1	6	−10	NF<15dB (6 V, 0.1mA, 1 kHz)				250*	3.5		138	
	〃 2379	東芝	PA	Si.EP	35	17	1.4A	15W (T_c=25°C)	175	1mA	15	80	5	1 A			P_o> 6 W, η>60% (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=1W)					15		325	
	〃 2380	〃	〃	〃	35	17	2.8A	30W (T_c=25°C)	175	1.5mA	15	>10	5	1.5A			P_o>12W, η>60% (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=3W)					28		325	
	〃 2381	〃	〃	〃	35	17	6 A	50W (T_c=25°C)	175	1mA	15	>10	5	3 A			P_o>25W, η>60% (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=10W)					<80		325	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC2382	東芝	PA	Si.EP	40	18	12A	100W (Tc=25°C)	175	2mA	15	>10	5	10A			P_o>50W, η>60% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=15W)					120		281	
〃 2383	〃	〃	Si. E	160	160	1 A	900	150	1	150	60~320	5	200	5	−200					>20*	<20	20	241	2SA1013 とコンプリ
★ 〃 2384	〃	〃	〃	160	160	1 A	10W (Tc=25°C)	150	1	150	60~320	5	200	5	−200					>20*	<20	20	249	2SA1014 とコンプリ
★ 〃 2385	三菱	AF.LN.RF	Si.EP	70	70	100	200	125	0.1	50	250~1200	6	1	6	−10	V_{NO}<300mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				130*	11.5	12	138B	
★ 〃 2386	〃	RF	〃	70	70	300	500	125	0.1	70	600	6	1	6	−10					125*	12.5	10	138B	
★ 〃 2387	日立	SW	Si. T	500	400	8 A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	3 A			t_{on}=1μs, t_f=0.6μs t_{stg}=1.5μs							102	
〃 2388	富士通	SW.PA	Si.TMe	450	400	4 A	75W (Tc=25°C)	175	100	450	20	5	2 A			t_r=0.25μs, t_f=0.45μs t_{stg}=1.3μs							102	
〃 2389	ローム	AF.LN	Si.EP	120	120	50	300	125	0.5	100	180~820	6	2	12	−2	V_{NO}<150mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				140*	2.5		138	2SA1038 とコンプリ
〃 2390	〃	〃	〃	80	80	50	300	125	0.5	75	180~820	6	2	12	−2	V_{NO}<150mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				140*	2.5		138	2SA1039 とコンプリ
〃 2391	東芝	PA	〃	35	17	800	7.5W (Tc=25°C)	175	1mA	15	>10	5	500			P_o>3W, η>50% (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=0.4W)					<10		325	
★ 〃 2392	〃	〃	〃	35	18	3.5A	30W (Tc=25°C)	175	1mA	15	>10	5	1 A			P_o>15W, η>60% (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=6W)					30		325	
★ 〃 2393	〃	〃	Si. E	80	80	4 A	12.5W (Tc=25°C)	150	15	40	50	5	2 A			P_o=8W (f=28MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.4W)							268	
★ 〃 2394	〃	〃	Si.EP	45	45R	6 A	20W (Tc=25°C)	150	100	35	20~100	5	1 A			P_o=16W, η>60% (f=50MHz, V_{CC}=12V, P_i=3W)					110		268	
〃 2395	〃	〃	〃	40	18	5 A	40W (Tc=25°C)	150			>20	5	1 A	5	−1 A	P_o=10W (PEP) (f=28MHz, V_{CC}=12.5V, P_i<0.2W)				200*	<150		325	
〃 2396	日立	AF	Si. E	60	60	100	400	150	0.1	50	250~1200	12	2	12	−2					90*	3		138	2SA1025 とコンプリ
★ 〃 2397	〃	PA	〃	60	60R	8 A	25W (Tc=25°C)	150	1	45	100~200	10	2 A	10	−100	P_o>18W (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=1W)				100	120		268	
★ 〃 2398	ソニー	PA.SW	Si.EPa	100	100	10A	95W (Tc=25°C)	120	10	50	>50	2	100	2	−1A					80*	240		102	2SA1028 とコンプリ
〃 2399	日立	RF	Si.EP	30	20	20	310	125	0.5	10	35~200	6	1	6	−5	G_{pe}=20dB, NF=3.5dB (6V, 1mA, 100MHz)				940*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138D	
〃 2400	〃	SW	〃	40	20	100	310	125	0.25	20	100	1	10	10	−10	t_{on}<10ns, t_{off}<15ns t_{stg}<7ns				1200*	1.8		138D	
〃 2401	〃	RF.SW	Si. P	40	30	300	310	125	0.1	30	10000	5	10	5	−10	t_{on}<150ns, t_{off}<1500ns t_{stg}<800ns				200*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138D	ダーリントン
〃 2402	富士通	SW.PA	Si.TMe	300	200	15A	150W (Tc=25°C)	175	100	300	20	5	5 A			t_r=1μs, t_f=0.7μs t_{stg}=1.6μs							102	
〃 2403	〃	〃	〃	300	200	40A	300W (Tc=25°C)	175	100	300	20	5	20A			t_r=1μs, t_f=1μs t_{stg}=2μs							41	
〃 2404	松下	RF	Si.EP	30	20	15	100	125			>40	6	1	6	−1	G_{pe}=24dB, NF=3.3dB (f=100MHz)				650*	C_{re} 0.8		176	
〃 2405	〃	AF.LN	〃	35	35	50	200	125	0.1	10	180~1040	5	2			V_{NO}=110mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)							176	2SA1034 とコンプリ
〃 2406	〃	〃	〃	55	55	50	200	125	0.1	10	180~1040	5	2			V_{NO}=110mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)							176	2SA1035 とコンプリ
〃 2407	日電	RF	Si. E	35	18	150	600	150	0.5	20	60	10	50			P_o=160mW (f=500MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=5mW)					1		138C	
〃 2408	〃	〃	〃	35	18	150	600	150	0.5	20	100	10	50	10	−50	$\|S_{21e}\|^2$=21dB (10V, 50mA, 200MHz)				3500*	1.25		138C	
〃 2409	ローム	AF	Si.EP	50	40	100	300	125	0.5	30	180~560	6	1	12	−2	NF=0.5dB (1kHz, 6V, 30nA)				180*	2		138	
〃 2410	〃	RF.IF.Conv Mix.Osc	〃	40	32	100	250	125	0.5	24	39~180	6	2	12	−2					230*	1.8		138	
〃 2411	〃	AF.Osc.SW	〃	40	32	500	200	125	1	20	82~390	3	10	5	−20					250*	6		335	2SA1036 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	r_{bb} h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC2412	ローム	AF.RF Osc.SW	Si.EP	50	40	100	200	125	0.5	30	120~560	6	1	12	−2					180 *	2		335	2SA1037とコンプリ
	〃 2413	〃	RF.IF.Osc	〃	40	25	50	200	125	0.5	24	56~270	6	1	6	−1					300 *	1.3		335	
★	〃 2414	松下	SW	Si.TMe	500	400	2 A	70W (Tc=25°C)	150	100	500	>8	5	1 A	10	−200	t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs				11 *			102	
★	〃 2415	〃	〃	〃	500	400	7 A	90W (Tc=25°C)	150	100	500	>8	5	3 A	10	−500	t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs				11 *			102	
★	〃 2416	〃	〃	〃	500	400	10A	120W (Tc=25°C)	150	100	500	>8	5	5 A	10	−500	t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs				11 *			102	
★	〃 2417	東芝																							
★	〃 2418	〃																							
★	〃 2419	〃	PA	Si.E	65	40	1 A	6 W (Tc=25°C)	150	100	30	50	3	150			P_o=3 W (f=175MHz, V_{CC}=28V, P_i=0.25W)							84B	
	〃 2420	〃	〃	Si.EP	40	18	6 A	70W (Tc=25°C)	150	2mA	15	>10	5	5 A			P_o>32W, η>60% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=4W)					110		316	
	〃 2421	富士電機	〃	Si.TP	200	150	5 A	100W (Tc=25°C)	150	1mA	200	700	4	1 A	12	−500					30 *	35	100 *	102	
	〃 2422	〃	〃	〃	150	70	5 A	100W (Tc=25°C)	150	1mA	150	700	4	1 A	12	−500					40 *	60	80 *	102	
	〃 2423	〃	〃	〃	200	150	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	200	700	4	1 A	12	−500					30 *	35	100 *	321	
	〃 2424	〃	〃	〃	150	70	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	150	700	4	1 A	12	−500					40 *	60	80 *	321	
★	〃 2425	富士通	AF.PA	〃	300	300	300	1.5W	175	1	270	80	10	50							20 *			268	
★	〃 2426	〃																							
	〃 2427	〃	SW	Si.TP	500	400	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	450	20	5	2 A			t_r<0.3μs, t_f<0.4μs t_{stg}<2.2μs							268	
	〃 2428	〃	SW.PA	Si.EP	180	180	12A	120W (Tc=25°C)	175	50	180	100	5	500	10	−1A					60 *	200		102	
	〃 2429	〃	SW	〃	450	400	15A	150W (Tc=25°C)	175	100	450	15	5	10A	10	−2A	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.5μs				30 *	240		102	○
	〃 2430	〃	SW.PA	〃	120	120	10A	100W (Tc=25°C)	175	50	120	100	5	1 A	10	−1A	t_r=0.2μs, t_f=0.12μs t_{stg}=0.7μs				80 *	200		102	2SA1040とコンプリ
	〃 2431	〃	〃	〃	120	120	15A	100W (Tc=25°C)	175	50	120	100	5	1.5A	10	−1A	t_r=0.2μs, t_f=0.12μs t_{stg}=0.7μs				80 *	200		102	2SA1041とコンプリ
	〃 2432	〃	〃	〃	70	70	15A	100W (Tc=25°C)	175	50	70	100	5	1.5A	10	−1A	t_r=0.2μs, t_f=0.12μs t_{stg}=0.7μs				80 *	200		102	2SA1042とコンプリ
	〃 2433	〃	〃	〃	120	120	30A	150W (Tc=25°C)	175	50	120	100	5	3 A	10	−2A	t_r=0.28μs, t_f=0.15μs t_{stg}=0.7μs				80 *	350		103	2SA1043とコンプリ
	〃 2434	〃	〃	〃	70	70	30A	150W (Tc=25°C)	175	50	70	100	5	3 A	10	−2A	t_r=0.28μs, t_f=0.15μs t_{stg}=0.7μs				80 *	350		103	2SA1044とコンプリ
	〃 2435	〃	〃	〃	100	100	10A	100W (Tc=25°C)	175	50	100	3000	3	2 A			t_r=0.4μs, t_f=0.4μs t_{stg}=1.5μs							102	ダーリントン 2SA1045とコンプリ
★	〃 2436	〃	〃	〃	100	100	15A	100W (Tc=25°C)	175	50	100	3000	3	3 A			t_r=0.4μs, t_f=0.4μs t_{stg}=1.5μs							102	ダーリントン 2SA1046とコンプリ
	〃 2437	富士電機	SW	Si.TP	450	400	7 A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	4	3 A			t_{on}<1.5μs, t_f<1.5μs t_{stg}<3μs							102	
	〃 2438	〃	〃	〃	150	100	10	60W (Tc=25°C)	150	100	150	120	5	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs							268	
	〃 2439	〃	〃	〃	150	100	7 A	50W (Tc=25°C)	150	100	150	120	5	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs							268	
	〃 2440	〃	〃	〃	450	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	2 A			t_{on}<1.5μs, t_f<1.3μs t_{stg}<4μs							268	
	〃 2441	三洋	PA	Si.EP	180	160	80	1 W	150	1	120	60~320	5	10	10	−10					150 *	2.7		296	2SA1047とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC2442	富士電機	SW	Si.TP	600	600R	30A	200W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	> 8	5	25A			t_{on}< 2 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 7 μs							266	
	〃 2443	〃	〃	〃	600	600R	50A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	> 8	5	40A			t_{on}< 2 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 7 μs							254	
★	〃 2444	東芝	〃	Si.TMe	500	400	30A	250W (Tc=25°C)	150	100	500	>15	5	20A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.3μs t_{stg}=1.7μs					320		266	
★	〃 2445	〃	〃	〃	250	200	30A	250W (Tc=25°C)	150	100	250	>10	5	20A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.3μs t_{stg}=1.7μs					360		266	
	〃 2446																								
★	〃 2447	松下	RF	Si. EP	20	10	50	250	175	0.05	10	>25	5	50	5	−50					1600*	1.3		50C	
	〃 2448	富士電機	SW	Si.TP	650	600	7 A	80W (Tc=25°C)	150	2 mA	650	15	5	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							102	
	〃 2449	〃	〃	〃	650	600	7 A	80W (Tc=25°C)	150	2 mA	650	15	5	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<1.5μs							102	
	〃 2450	〃	〃	〃	750	700	7 A	80W (Tc=25°C)	150	2 mA	750	15	5	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							102	
	〃 2451	〃	〃	〃	750	700	7 A	80W (Tc=25°C)	150	2 mA	750	15	5	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<1.5μs							102	
	〃 2452	〃	〃	〃	850	800	7 A	80W (Tc=25°C)	150	2 mA	850	15	5	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							102	
	〃 2453	〃	〃	〃	850	800	7 A	80W (Tc=25°C)	150	2 mA	850	15	5	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<1.5μs							102	
	〃 2454	松下	RF	Si. P	50	40	30	400	150			>38	10	7	10	− 5	G_{pe}=25dB (f=58MHz)				550*			337B	
★	〃 2455	〃	〃	〃	30	20	20	250	150			>25	10	2	10	− 2	G_{pe}>15dB, NF= 3 dB (f=200MHz)				>450*			337A	
★	〃 2456	東芝	PA	Si. T	300	300	100	10W (Tc=25°C)	150	1	240	40~170	10	50	10	−30					>50*	< 5	15	342	
★	〃 2457	〃																							
	〃 2458	〃	AF	Si. E	50	50	150	200	125	0.1	50	70~700	6	2	10	− 1	NF< 3 dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				>80*	2		287	2SA1048 とコンプリ
	〃 2459	〃	〃	〃	120	120	100	200	125	0.1	120	200~700	6	2	6	− 1	NF= 1 dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				100*	3		287	2SA1049 とコンプリ
★	〃 2460	〃	PA	〃	140	140	12A	100W (Tc=25°C)	150	10	140	55~240	5	1 A	10	− 1 A					90*	130	2*	102	2SA1050 とコンプリ ○
★	〃 2461	〃	〃	〃	150	150	15A	150W (Tc=25°C)	150	10	150	55~240	5	1 A	10	− 1 A					80*	200	2*	102	2SA1051 とコンプリ ○
	〃 2462	日立	AF	〃	50	40	100	150	150	0.5	30	100~500	12	2	12	− 2					230*	1.8	100	176	
	〃 2463	〃	〃	〃	55	50	100	150	150	0.5	30	250~1200	12	2	12	− 2					230*	1.8	$C_c r_{bb'}$ 12ps	176	
	〃 2464	〃	〃	〃	30	25	20	200	150	0.1	25	>30	10	3	10	− 3		G_{pe}=16dB (10V, 3 mA, 900MHz)			900*	0.55	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	240A	フォワードAGC
	〃 2465	〃	RF	Si. E	20	20	20	200	150	0.1	20	20~200	10	2	10	− 2	G_{pe}=23dB (V_{CE}=10V, I_C=2mA, f=200MHz)				550*	Cre 0.23	$C_c r_{bb'}$ 10ps	240C	フォワードAGC
	〃 2466	〃	Mix.	〃	30	20	50	200	150	0.1	15	30~200	10	5	10	− 5	G_{pb}=18dB(10V, 5mA, 900MHz) G_{cb}=13dB(10V, 2mA, 930MHz)				2200*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 10ps	240A	
	〃 2467	〃	〃	〃	30	20	50	200	150	0.5	10	>30	10	10	10	−10	G_{ce}=23dB (V_{CE}=10V, I_C=2mA, f=200MHz)				900*	Cre 0.27	$C_c r_{bb'}$ 13ps	240C	フォワードAGC
	〃 2468	〃	RF. Osc	Si.EP	30	20	50	200	150	0.5	15	>40	10	10	10	−10	V_{osc}=490mV (V_{CC}=9.2V, I_C=10mA, f=930MHz)				>900*	<1.5	$C_c r_{bb'}$ 10ps	240B	
	〃 2469	〃	Osc.	〃	30	20	50	200	150	0.5	15	>40	10	10	10	−10		V_{osc}=500mV (7.5V, 8mA, 300MHz)			>600*	<1.5	$C_c r_{bb'}$ 10ps	240B	
	〃 2470	〃	RF	Si. E	30	20	50	200	150	0.5	24	>20	10	5	10	− 5	G_{pe}=16dB, NF= 4 dB (V_{CC}=10V, I_C=7mA, f=200MHz)				2200*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 10ps	240C	フォワードAGC
	〃 2471	〃	Osc.	〃	30	30	50	310	150	0.1	24	>20	10	5	10	− 5		V_{osc}=500mV (9 V, 7 mA, 930MHz)			2000*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138C	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★ 2SC2472	日立	RF.LN	Si.E	30	20	50	300	125	0.5	24	>20	10	5	10	−5	G_{pe}>13dB, NF<5dB (V_{CC}=10V, I_C=5mA, f=500MHz)				2200*	0.85	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138C	
★ 〃 2473	〃	RF	〃	30	20	50	300	125	0.5	24	>20	10	5	10	−5	G_{pe}=15dB, NF<5dB (V_{CC}=10V, I_C=7mA, f=200MHz)				2200*	C_{re} 0.5	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138C	
〃 2474	日電	SW	〃	60	40	200	600	150	0.1	30	150	1	10			t_{on}<70ns, t_{off}<250ns t_{stg}<200ns							138D	
〃 2475	〃	〃	〃	60	30	600	600	150	0.01	50	200	10	150			t_{on}<35ns, t_{off}<285ns t_{stg}<225ns							138D	
〃 2476	〃	〃	〃	30	25	200	600	150	0.05	20	150	1	2			t_{on}<70ns, t_{off}<250ns t_{stg}<200ns							138D	
〃 2477	〃	〃	〃	60	40	600	600	150	0.1	35	150	1	150			t_{on}<35ns, t_{off}<300ns t_{stg}<225ns							138D	
〃 2478																								
〃 2479																								
〃 2480	松下	RF.Osc.Mix	Si.EP	30	20	50	100	125			>25	10	2	10	−2	G_{pe}=20dB (f=100MHz)				1200*	C_{re} 1		176	
★ 〃 2481	東芝	PA	Si.E	150	150	1.5A	20W (T_c=25°C)	150	1	150	60~320	5	200	5	−200					>20*	13	20	342	2SA1021 とコンプリ
〃 2482	〃	AF.RF	Si.T	300	300	100	900	150	1	240	30~150	10	20	10	−20					>50*	3		241	
〃 2483	〃	PA	Si.E	160	160	1.5A	15W (T_c=25°C)	175	1	150	100~320	5	200	5	−200					120*	<20	20	178	2SA1195 とコンプリ
★ 〃 2484	松下	〃	Si.TP	80	80	5A	60W (T_c=25°C)	150	50	80	90	5	1A	5	−500					20*	100	10	365	2SA1060 とコンプリ
★ 〃 2485	〃	〃	〃	100	100	6A	70W (T_c=25°C)	150	50	100	90	5	1A	5	−500					20*	140	10	365	2SA1061 とコンプリ
★ 〃 2486	〃	〃	〃	120	120	7A	80W (T_c=25°C)	150	50	120	90	5	1A	5	−500					20*	190	10	365	2SA1062 とコンプリ
★ 〃 2487	〃	〃	Si.EMe	150	150	6A	80W (T_c=25°C)	150			40~280	5	1A	10	−500					50*			102	2SA1063 とコンプリ
★ 〃 2488	〃	〃	〃	150	150	8A	100W (T_c=25°C)	150	1mA	70	40~280	5	1A	10	−500					50*			102	2SA1064 とコンプリ
★ 〃 2489	〃	〃	〃	150	150	10A	120W (T_c=25°C)	150	1mA	70	40~280	5	1A	10	−500					50*			102	2SA1065 とコンプリ
〃 2490	富士通	〃	Si.EP	55	33	10A	90W (T_c=25°C)	175	1.6mA	20	50	5	6A			P_o=75W, η_c=65% (f=770MHz, V_{CC}=28V, P_i=25W)					48		168	
〃 2491	サンケン	PA.SW	Si.EMe	100	50	6A	50W (T_c=25°C)	150	100	100	600	4	1A	12	−500					30*	200	15	298	
★ 〃 2492	〃	PA	Si.EP	120	120	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	120	60	4	3A	12	−500					70*	100	60	102	
★ 〃 2493	〃	〃	〃	150	150	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	150	60	4	3A	12	−500					70*	100	60	102	
〃 2494	日電	〃	Si.E	25	12	750	8.75W (T_c=25°C)	200	100	20	60	7	100			P_o=1.8W (f=500MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=130mW)					C_{re} 4		326	
〃 2495	〃	〃	〃	25	12	1.5A	17.5W (T_c=25°C)	200	100	20	60	7	200			P_o=4.1W (f=500MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=1W)					C_{re} 8		326	
〃 2496	〃	〃	〃	35	18	10A	88W (T_c=25°C)	200	2mA	20	60	10	1A			P_o=37W (V_{CC}=13.5V, f=500MHz, P_i=10W)							368	
〃 2497	松下	RF	Si.EP	70	50	1.5A	1.2W	150	10	20	120	5	1A	5	−500					150*	35	110	222	2SA1096 とコンプリ
〃 2498	東芝	〃	Si.E	30	20	50	300	125	1	10	80	10	10	10	−10	NF=2.5dB (10V, 5mA, 500MHz)				3500*	1.15	40*	138C	
〃 2499	〃	〃	〃	20	20	30	300	125	0.1	10	80	10	5	10	−10	NF=1.7dB (10V, 3mA, 500MHz)				4000*	0.9	45*	138C	
〃 2500	〃	SW.PA	〃	30	10	2A	900	150	0.1	30	140~600	1	500	1	−500					150*	27		241	2SA1160 とコンプリ
〃 2501	新電元	SW	Si.T	500	400	3A	40W (T_c=25°C)	150	100	500	20	2	1.5A	10	−300	t_{on}<1μs, t_f<0.7μs t_{stg}<3μs				20*			268	T3V40F1

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC2502	新電元	SW	Si. T	500	400	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	500	20	2	3 A	10	−600	t_{on}< 1 μs, t_f<0.7 μs t_{stg}< 3 μs				20 *			268	T6V40F1
★ 〃 2503	〃	〃	〃	500	400	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	500	20	〃2	4 A	10	−1 A	t_{on}< 1 μs, t_f<0.7 μs t_{stg}< 3 μs				20 *			198	T8V40F1
★ 〃 2504	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	20	2	5 A	10	−1 A	t_{on}< 1 μs, t_f<0.7 μs t_{stg}< 3 μs				20 *			198	T10V40F1
〃 2505	〃	〃	〃	500	400	3 A	60W (Tc=25°C)	150	100	500	20	2	1.5A	10	−300	t_{on}< 1 μs, t_f<0.7 μs t_{stg}< 3 μs				20 *			204	T3M40F1
〃 2506	〃	〃	〃	500	400	6 A	80W (Tc=25°C)	150	100	500	20	2	3 A	10	−600	t_{on}< 1 μs, t_f<0.7 μs t_{stg}< 3 μs				20 *			204	T6M40F1
〃 2507	〃	〃	〃	500	400	20A	200W (Tc=25°C)	150	100	500	20	2	10A	10	−2 A	t_{on}< 1 μs, t_f<0.7 μs t_{stg}< 3 μs				20 *			103	T20M40F1
〃 2508	東芝	PA	Si.EP	40	18	6 A	50W (Tc=25°C)	175	1mA	15	10~150	5	3 A			P_o>27W, η>60% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=4.2W)					<80		325	
〃 2509	〃	〃	〃	40	18	5 A	20W (Tc=25°C)	150			>20	5	1 A			P_o>10W (PEP) (f=28MHz, V_{CC}=12.5V, P_i<0.4W)					<150		268B	
〃 2510	〃	〃	〃	60	35	20A	250W (Tc=25°C)	175			>10	5	10A			P_o>150W (PEP) (f=28MHz, V_{CC}=28V, P_i=7W)					450		281	
★ 〃 2511	日立	RF. Mix	Si. E	60	60	100	320	125	0.2	25	41~175	3	1	6	−2		G_{pe}=20dB (6 V, 1 mA, 100MHz)			150 *	2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138	
〃 2512	〃	〃	〃	30	20	50	300	150	0.5	10	>30	10	10	10	−10		G_{pb}=20dB (10V, 2 mA, 200MHz)			900 *	C_{re} 0.35	$C_c r_{bb'}$ <20ps	138C	
〃 2513																								
〃 2514																								
〃 2515																								
〃 2516	日電	SW	Si. E	150	60	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	60	40~200	5	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							268	2SA1069 とコンプリ ○
〃 2517	〃	〃	〃	150	100	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	40~200	5	2 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs							268	
〃 2518	〃	〃	Si. T	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	10	400	20~80	5	500			t_{on}< 1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}<2.5μs							268	
★ 〃 2519	松下	RF	Si. EP	30	20	30	250	125	1	10	230	10	1	10	−1					230 *	C_{re} 1.3	20	276	
★ 〃 2520	富士通																							
★ 〃 2521	〃																							
〃 2522	〃	PA	Si. P	120	120	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	120	110	5	1 A	10	−1 A					80 *	180	1.5 *	102	2SA1072 とコンプリ ○
〃 2523	〃	〃	〃	160	160	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	160	110	5	1 A	10	−1 A					80 *	180	1.5 *	102	2SA1073 とコンプリ
★ 〃 2524	〃																							
〃 2525	〃	PA	Si. P	120	120	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	120	110	5	1 A							80 *			163	2SA1075 とコンプリ
〃 2526	〃	〃	〃	160	160	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	160	110	5	1 A							80 *			163	2SA1076 とコンプリ
〃 2527	〃	〃	〃	120	120	10A	60W (Tc=25°C)	150	50	120	110	5	1 A	10	−1 A					80 *	180	1.5 *	268	2SA1077 とコンプリ
〃 2528	〃	〃	〃	120	120	2 A	25W (Tc=25°C)	150	1	120	120	5	300	10	−500					160 *	60	12 *	268	2SA1078 とコンプリ
〃 2529	〃	〃	〃	160	160	2 A	25W (Tc=25°C)	150	1	160	120	5	300	10	−500					160 *	60	12 *	268	2SA1079 とコンプリ
〃 2530	〃	〃	〃	40	40	500	20W (Tc=25°C)	150	0.1	40	150	5	10	10	−10					35 *	25	15 *	268	
★ 〃 2531	東芝																							

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC2532	東芝	RF. AF	Si. E	40	40	300	150	125	0.1	40	25000	5	10	10	−10					100*	6	100	176	ダーリントン
★ 〃 2533	〃																							
〃 2534	〃	SW	Si. T	500	400	2 A	20W (Tc=25°C)	150	100	400	>20	5	500			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							268	
〃 2535	〃	〃	〃	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	400	>10	5	3 A	5	−1 A	t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							268	
★ 〃 2536	〃	〃	〃	500	400	7 A	80W (Tc=25°C)	150	100	400	>10	5	3 A			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							179	
★ 〃 2537	三菱	〃	Si. TP	410	350	10A	100W (Tc=25°C)	150	30	400	30	5	5 A			t_r=0.25μs, t_f=0.35μs t_{stg}=2.7μs							341	
〃 2538	〃	RF.PA	Si.EP	40	17	400	700	135	100	15	80	10	100			P_o=600mW, η=55% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=50mW)							242	
〃 2539	〃	〃	〃	35	17	4 A	35W (Tc=25°C)	175	1mA	25	50	10	100			P_o=17W, η=65% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.5W)							272A	
〃 2540	〃	〃	〃	35	17	10A	75W (Tc=25°C)	175	2.5mA	15	60	10	200			P_o=45W, η=70% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=6W)							303	
★ 〃 2541	〃	SW	Si. TP	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	30	450	20～45	5	5 A	5	−1 A	t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs				16*			341	
〃 2542	富士電機	〃	〃	450	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	450	>10	5	2 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs							268	
〃 2543	日立	AF.LN	Si. E	90	90	100	400	150	0.1	50	250～1200	12	2	12	−2		NF=0.2dB (6V, 10mA, 1kHz)			90*	3		138	2SA1081 とコンプリ
〃 2544	〃	〃	〃	120	120	100	400	150	0.1	50	250～800	12	2	12	−2		NF=0.2dB (6V, 10mA, 1kHz)			90*	3		138	2SA1082 とコンプリ
〃 2545	〃	AF	〃	60	60	100	400	150	0.1	50	250～1200	12	2	12	−2		e_n<0.5nV/√Hz (6V, 10mA, 1kHz)			90*	3		138	2SA1083 とコンプリ
〃 2546	〃	〃	〃	90	90	100	400	150	0.1	50	250～1200	12	2	12	−2		e_n<0.5nV/√Hz (6V, 10mA, 1kHz)			90*	3		138	2SA1084 とコンプリ
〃 2547	〃	〃	〃	120	120	100	400	150	0.1	50	250～800	12	2	12	−2		e_n<0.5nV/√Hz (6V, 10mA, 1kHz)			90*	3		138	2SA1085 とコンプリ
〃 2548	東芝	RF	〃	20	10	30	250	125	1	10	120	5	10	5	−10		NF=2.2dB (0.5GHz)			4000*	0.85	65*	138C	
★ 〃 2549	ソニー	〃	〃	15	15	30	250	100	I_{CES} 0.2	15	20～200	10	3			$\|S_{21e}\|^2$=10dB (10V,3mA,f=800MHz)	NF=1.0dB (10V,3mA,f=500MHz)				0.8		138C	
〃 2550	東芝	RF.SW	〃	60	50	200	300	175	0.1	60	70～400	1	10	10	−10	t_{on}=100ns, t_{sf}=450ns t_{stg}=400ns				250*	3	30	49C	2SA1090 とコンプリ
〃 2551	〃	RF	Si. T	300	300	100	400	150	0.1	300	90	10	20	10	−20					80*	3	15	138	2SA1091 とコンプリ
〃 2552	〃	SW	〃	500	400	2 A	20W (Tc=25°C)	150	100	400	30	5	100			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							268	
〃 2553	〃	〃	〃	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	400	20	5	3 A			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							268	
★ 〃 2554	〃																							
〃 2555	〃	SW	Si. T	500	400	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	400	17	5	4 A			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							203	
〃 2556	松下	RF	Si. EP	130	40	1 A	1.2W	150	0.1	20	220	0.5	1 A	10	−50					200*	20	80	222	○
★ 〃 2557	〃	〃	〃	60	55	50	400	150	0.1	30	450	5	2	5	−20					220*	5	8	138	2SA1092 とコンプリ
〃 2558	日電	PA	Si. E	35	18	250	8.3W (Tc=25°C)	200	50	20	60	10	100			P_o=1.25W (f=860MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.1W)					Cre 2.3		326	
〃 2559	〃	〃	〃	35	18	1.5A	17.5W (Tc=25°C)	200	150	20	60	10	300			P_o= 5 W (f=860MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.9W)					Cre 10		326	
〃 2560																								
★ 〃 2561	松下	RF	Si. EP	30	20	30	250	125	0.1	10	110	10	1	10	−1					250*	Cre 0.9	10	276	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SC2562	東芝	SW	Si. E	60	50	5 A	25W (T_c=25°C)	150	1	50	70~240	1	1 A	4	−1A	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_{stg}=1 μs				120 *	80		268	2SA1012 とコンプリ	
	〃 2563	〃	PA	〃	120	120	8 A	80W (T_c=25°C)	150	50	120	120	5	1 A	10	−1A					90 *	90	2 *	179		
	〃 2564	〃	〃	〃	140	140	12A	120W (T_c=25°C)	150	10	140	55~240	5	1 A	10	−1 A					90 *	130	2 *	125	2SA1094 とコンプリ	
	〃 2565	〃	〃	〃	160	160	15A	150W (T_c=25°C)	150	10	160	55~240	5	1 A	10	−1 A					80 *	200	2 *	125	2SA1095 とコンプリ	
★	〃 2566	日電	RF	〃	35	18	250	6 W (T_c=25°C)	200	10	20	100	10	80	10	−60	$\|S_{21e}\|^2$= 9 dB (1GHz) NF=5.5dB (10V, 50mA, 1GHz)				2300*			85B		
	〃 2567	松下	〃	Si. EP	35	35	50	100	125	0.1	10	350	5	2	5	−20					320 *	3.5	45	293		○
	〃 2568	日電	PA	Si. T	300	300	200	10W (T_c=25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	−10					80 *	3.5	30	225		
	〃 2569	富士電機	SW	Si. TP	150	100	6 A	40W (T_c=25°C)	150	100	150	80	4	2 A				t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2 μs						321		
	〃 2570	日電	RF	Si. E	25	12	70	250	150	0.1	15	40~200	10	20	10	−20		$\|S_{21e}\|^2$ =10dB (f=1GHz)			5000*	C_{re} 0.7		138C		○
★	〃 2571	ソニー																								
	〃 2572	日電	SW	Si. E	60	40	200	360	200	0.1	40	200	1	10	10	−10		t_{on}<80ns, t_{off}<420ns t_{stg}<320ns			300 *	3.5		49C		
★	〃 2573	三菱																								
★	〃 2574	〃																								
★	〃 2575	〃	AF. RF	Si. E	50	50	200	300	125	0.1	50	90~800	6	1	6	−10	NF<15dB (f=1kHz, 6V, 0.1mA)				200 *	3.5		138B		
★	〃 2576	〃																								
★	〃 2577	サンケン	PA	Si. TMe	120	80	6 A	60W (T_c=25°C)	150	100	120	80	4	2 A	12	−500					20 *	110	12	324		
★	〃 2578	〃	〃	〃	140	100	7 A	70W (T_c=25°C)	150	100	140	80	4	3 A	12	−500					20 *	150	8	324		
★	〃 2579	〃	〃	〃	160	120	8 A	80W (T_c=25°C)	150	100	160	80	4	3 A	12	−500					20 *	200	10	324		
★	〃 2580	〃	〃	〃	180	120	9 A	90W (T_c=25°C)	150	100	180	80	4	3 A	12	−500					20 *	250	7	324		
★	〃 2581	〃	〃	〃	200	140	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	200	80	4	3 A	12	−500					20 *	250	10	324		
	〃 2582	松下	RF	Si. EP	45	30	1 A	1.2W	150	0.1	20	160	10	500	10	−50					200 *	15	15	236		
★	〃 2583	日電																								
	〃 2584	〃	PA	Si. E	38	18	4 A	40W (T_c=25°C)	200	1.5mA	30	60	10	800			P_o=22W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=2.5W)							327		
	〃 2585	〃	RF	〃	25	12	65	400	200	1	8	100	8	7	8	−20	$\|S_{21e}\|^2$=11dB (2GHz) NF= 2 dB (8V, 7mA, 2GHz)				8500*			314		
	〃 2586	〃	PA	〃	35	18	400	7 W (T_c=25°C)	200	100	20	60	10	100			P_o=1.6W (f=500MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=0.2W)							84B		
★	〃 2587	〃	〃	〃	150	130	10A	120W (T_c=25°C)	150	50	130	150	5	1 A	5	−200					70 *	150	15	340		○
★	〃 2588	〃	〃	Si. T	130	130	12A	120W (T_c=25°C)	150	50	120	150	5	2 A	5	−1A					60 *	170	15	340		○
	〃 2589	〃	〃	Si. E	180	180	10A	200W (T_c=25°C)	150	50	160	90	5	2 A	5	−1A					60 *	300	15	102	2SA1109 とコンプリ	
	〃 2590	松下	〃	Si. EP	120	120	500	5 W	150			65~330	10	150	10	−50					250 *			222	2SA1110 とコンプリ	
	〃 2591	〃	〃	〃	150	150	1 A	20W (T_c=25°C)	150			90~330	10	150	10	−50					250 *			268	2SA1111 とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC2592	松下	PA	Si.EP	180	180	1 A	20W (Tc=25°C)	150			90~330	10	150	10	−50					250*	20		268	2SA1112とコンプリ
★	〃 2593	ソニー	RF	Si.E	20	20	50	140	60	0.001	3	700	3	1	4	−20					35*		$C_c r_{bb'}$ 1000ps	138D	双方向性
	〃 2594	松下	AF.PA	Si.EP	40	20	5 A	10W (Tc=25°C)	150	0.1	10	140~450	2	500	6	−50					150*	30		236	
★	〃 2595	〃	PA	〃	36	16	I_{CM} 1.2A	10W (Tc=25°C)	175	100	15	50	10	100	10	−100	P_o=0.9W, η=45% (f=840MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=0.1W)				4000*	5		338	
★	〃 2596	〃	〃	〃	36	16	I_{CM} 4 A	20W (Tc=25°C)	175	1 mA	15	50	10	200	10	−200	P_o=3.5W, η=55% (f=840MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=0.8W)				1500*	20		338	
★	〃 2597	〃	〃	〃	36	16	I_{CM} 6 A	30W (Tc=25°C)	175	2 mA	15	50	10	500	10	−500	P_o=9 W, η=50% (f=840MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=3W)				900*			338	
	〃 2598	富士通	Diff.SW	Si.P	20	10	70	200/unit	175	0.5	10	80	3	10			h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0				5000*		50*	264B	
	〃 2599	〃	RF.LN	Si.EP	20	13	20	200	175	0.5	10	80	8	7			NF=2.7dB (8V,3mA, f=4GHz)							262	
★	〃 2600	〃	RF	〃	25		40	350	200	1	15	80	12	20			P_o=17dBm, P_i=9 dBm (f=4GHz, V_{CC}=12V, I_C=20mA)				6000*			170	
★	〃 2601	三菱	Diff.	〃	70	70	200	200/unit.	125	0.1	50	300	6	1	6	−1	300	7.8k	3.4	14	100*	22	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	283	2素子複合
	〃 2602	〃	AF.LN	〃	70	70	200	500	125	0.1	70	250~1200	6	1	6	−10	V_{NO}<300mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				180*	7	3	138B	
	〃 2603	〃	〃	〃	50	50	200	300	125	0.1	50	90~800	6	1	6	−10	NF<15dB (1 kHz, 6 V, 0.1mA)				200*	2.5		175	
	〃 2604	日立	RF.LN	Si.E	30	30	100	200	125	0.5	18	250	12	2	12	−2	NF=3 dB (6 V, 0.1mA, 120Hz)				230*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138	
	〃 2605	〃	〃	〃	50	30	100	200	125	0.5	18	250	12	2	12	−2	NF=3 dB (6 V, 0.1mA, 120Hz)				230*	2.8	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138	
★	〃 2606	ソニー	RF	Si.T	300	300	50	950	120	0.2	200	60~200	5	3	10	−2					30*	2		174B	
★	〃 2607	サンケン	PA	Si.TMe	200	200	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	200	>30	4	5 A	12	−500	t_r=0.3μs, t_f=0.4μs t_{stg}=2.4μs				20*			102	2SA1116とコンプリ
★	〃 2608	〃	〃	〃	200	200	17A	200W (Tc=25°C)	150	100	200	>20	4	8 A	12	−1 A	t_r=0.5μs, t_f=0.6μs t_{stg}=1.8μs				20*			102	2SA1117とコンプリ
	〃 2609	三菱	RF.PA	Si.EP	55	35	15A	170W (Tc=25°C)	175	10mA	35	50	25	200			P_o=110W, η=60% (f=220MHz, V_{CC}=28V, P_i=25W)							303	
	〃 2610	日立	RF	Si.T	300	300	100	800	150	I_{CEO} 1	V_{CE} 250	30~200	20	20	20	−20					80*	<4		251	
	〃 2611	〃	〃	〃	300	300	100	1.25W	150	I_{CEO} 1	V_{CE} 250	30~200	20	20	20	−20					80*	<4		160	
	〃 2612	〃	SW	〃	500	400	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	1.5A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							268	
	〃 2613	〃	〃	〃	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	2.5A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							268	
★	〃 2614	〃	〃	〃	500	400	5 A	60W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	2.5A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							332	
	〃 2615	〃	〃	〃	500	400	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	4 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							332	
	〃 2616	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	5 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							102	
	〃 2617	〃	〃	〃	500	400	15A	125W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	7.5A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							102	
	〃 2618	〃	RF.AF	Si.E	35	35	500	150	150	0.5	20	60~320	3	10	6	−1					50*	5	9*	176	2SA1121とコンプリ
	〃 2619	〃	〃	〃	30	30	100	150	150	0.5	20	35~200	12	2	12	−2	NF=5 dB (6V, 2mA, 1MHz)				230*	<3.5	40	176	
	〃 2620	〃	RF.Osc	〃	30	20	20	100	150	0.5	10	35~200	6	1	6	−1					940*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 15ps	176	
	〃 2621	三洋	RF.PA	Si.TP	300	300	200	10W (Tc=25°C)	150	1	200	40~200	10	10	30	−10					>50*	<5		296	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★ 2SC2622																								
〃 2623	富士電機	SW. PA	Si. TP	450	400	20A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	20	5	8 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							102	
〃 2624	〃	SW	〃	450	400	5 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	2 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							211	
〃 2625	〃	〃	〃	450	400	10A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	5	4 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							211	
〃 2626	〃	〃	〃	400	300	15A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	400	>10	5	6 A			t_{on}<0.8μs, t_f<0.8μs t_{stg}< 2 μs							211	
〃 2627	三菱	PA	Si. EP	35	17	2 A	20W (Tc=25°C)	175	1 mA	25	80	10	100			P_o= 6 W, η=70% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=0.25W)							187	
〃 2628	〃	〃	〃	35	17	4 A	40W (Tc=25°C)	175	2 mA	25	30	10	100			P_o=18W, η=70% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i= 1 W)							187	
〃 2629	〃	〃	〃	35	17	8 A	60W (Tc=25°C)	175	3 mA	25	40	10	200			P_o=34W, η=70% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=3.5W)							187	
〃 2630	〃	〃	〃	35	17	14A	100W (Tc=25°C)	175	5 mA	25	40	10	200			P_o=60W, η=70% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=10W)							303	各リード・フランジ間絶縁
〃 2631	松下	AF	〃	150	150	50	750	150	1	100	90~450	5	10	10	−10	V_{NO}=150mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, G_V=80dB)				160*	2		138	2SA1123とコンプリ
〃 2632	〃	〃	〃	150	150	50	1 W	150	1	100	90~450	5	10	10	−10	V_{NO}=150mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, G_V=80dB)				160*	2		294	2SA1124とコンプリ
〃 2633	〃	〃	〃	150	150	50	1.5W	150	1	100	90~450	5	10	10	−10					160*	2		268	2SA1125とコンプリ
〃 2634	〃	〃	〃	60	55	100	400	150	0.1	10	180~700	5	2										138	2SA1127とコンプリ
〃 2635	日立	SW	Si. T	650	600	100	750	150	I_{CEO} 5	V_{CE} 500	35~200	20	20	10	−10					15*	10		84B	2SA1126とコンプリ
〃 2636	松下	Osc. Mix	Si. EP	30	20	50	400	150	100	30	>25	10	2	10	−10					1200*	C_{re} 0.8		151	
〃 2637	〃	RF	Si. TP	300	300	100	1.4W	150	100	300	50~250	50	10	30	−20					100*			161	
〃 2638	東芝	PA	Si. EP	35	17	2 A	15W (Tc=25°C)	175	100	15	>10	5	1 A			P_o> 6 W, η>60% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=0.5W)					<25		279	
〃 2639	〃	〃	〃	35	17	3.5A	35W (Tc=25°C)	175	1 mA	15	>10	5	1 A			P_o>15W, η>60% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=1.3W)					<80		279	
〃 2640	〃	〃	〃	40	17	6 A	70W (Tc=25°C)	175	2 mA	15	>10	5	5 A			P_o>28W, η>60% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i= 4 W)					110		279	
〃 2641	〃	〃	〃	35	17	1.4A	15W (Tc=25°C)	175	1 mA	15	>10	5	1 A			P_o> 6 W, η>60% (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i= 1 W)					15		279	
〃 2642	〃	〃	〃	35	17	2.8A	30W (Tc=25°C)	175	1.5mA	15	>10	5	1.5A			P_o>12W, η>60% (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i= 3 W)					28		279	
〃 2643	〃	〃	〃	35	18	6 A	50W (Tc=25°C)	175	1 mA	15	>10	5	3 A			P_o>25W, η>60% (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i= 8 W)					<80		279	
〃 2644	〃	RF		25	12	120	500	125	10	10	50	5	50	10	−30	NF= 3 dB (10V, 10mA, 1 GHz)				4000*	1.6	50*	138C	
★ 〃 2645	松下	Osc. Mix	Si. EP	30	20	50	200	135			>25	10	2		−10	G_p=20dB (f=200MHz)				1200*			337C	
★ 〃 2646	〃	RF. Mix. Osc.	〃	30	20	50	200	125	0.1	10	120	10	2	10	−15					1200*	2	15	276	
〃 2647	〃	RF	〃	30	20	30	250	150	10	30	40~50	10	1	10	− 1					230*	C_{re} 1.3	Z_{rb} <60Ω	151	
〃 2648	東芝	PA	Si. E	35	17	3.5A	30W (Tc=25°C)	175	1 mA	15	50	5	1 A			P_o=17W (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i= 6 W)							316	
〃 2649	〃	〃	〃	35	17	6 A	50W (Tc=25°C)	175	1 mA	15	50	5	3 A			P_o=22W (f=470MHz, V_{CC}=12.6V, P_i= 6 W)							316	
〃 2650	〃	SW	Si. T	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	20	5	5 A			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							125	
★ 〃 2651	〃	PA	Si. E	45	18	25A	250W (Tc=25°C)	175	12mA	15	50	5	10A			P_o=90W PEP (V_{CC}=12.5V, f=28MHz, P_i=10W PEP)							281	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC2652	東芝	PA	Si. E	85	55	20A	300W (Tc=25°C)	175	12mA	15	50	5	10A			P_o=220W PEP (V_{CC}=50V, f=28MHz, P_i=10W PEP)							281	
★ 〃 2653	松下	SW	Si. TP	350	300	200	15W (Tc=25°C)	150	2	200	40~250	10	10	30	−10					>50*	<4.5		161	水平偏向用
〃 2654	日電	〃	Si. E	100	40	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	40	40~320	1	3 A			t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2.5μs							268	2SA1129 とコンプリ
〃 2655	東芝	PA	〃	50	50	2 A	900	150	1	50	70~240	2	500	2	−500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_{stg}=1 μs				100*	30	7*	241	2SA1020 とコンプリ
〃 2656	富士電機	SW	Si. TP	450	400	7 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	4	3 A			t_{on}<1.5μs, t_f<1.5μs t_{stg}<3 μs							211	
★ 〃 2657	松下	〃	Si. TMe	800	500	1.5A	70W (Tc=25°C)	150	100	800	>8	5	1 A	10	−200	t_{on}<1 μs, t_f<1.2μs t_{stg}<3 μs				2.5*			102	○
★ 〃 2658	〃	〃	〃	800	500	5 A	90W (Tc=25°C)	150	100	800	>8	5	3 A	10	−500	t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<3 μs				3*			102	○
★ 〃 2659	〃	〃	〃	800	500	7 A	120W (Tc=25°C)	150	100	800	>8	5	5 A	10	−500	t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2.5μs				3.5*			102	○
〃 2660	〃	PA	Si. TP	200	150	2 A	30W (Tc=25°C)	150	50	200	60~200	10	400										268	2SA1133 とコンプリ ○
★ 〃 2661																								
★ 〃 2662	東芝	RF. SW	Si. E	100	60	3 A	8 W (Tc=25°C)	150	0.1	100	90	2	1 A	10	−50					50*	30	15	84B	
★ 〃 2663	〃																							
★ 〃 2664	〃	SW	Si. E	100	60	3 A	10W (Tc=25°C)	175	0.1	100	90	2	1 A	10	−50					50*	30	15	97C	
★ 〃 2665	サンケン	PA	Si. TMe	100	80	4 A	55W (Tc=25°C)	150	1 mA	100	90	4	1 A	12	−200					10*	70	16	324	
〃 2666	東芝	〃	Si. E	35	17	3.5A	30W (Tc=25°C)	175	1 mA	15	50	5	1 A			P_o=7 W (f=270MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=1 W)							260	
〃 2667	〃	〃	〃	35	17	6 A	45W (Tc=25°C)	175	1 mA	15	50	5	3 A			P_o=20W (f=270MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=6 W)							260	
〃 2668	〃	RF. Mix. Conv	Si. EP	40	30	20	100	125	0.5	40	40~200	6	1	6	−1	G_{pe}=18dB, NF=2.5dB (6 V, 1 mA, 100MHz)				550*	C_{re} 0.7	$C_{r\,rbb'}$ <30ps	287	
〃 2669	〃	〃	〃	35	30	50	200	125	0.1	35	40~240	12	2	10	−1	G_{pe}=30dB (6 V, 1 mA, 10.7MHz)				>100*	2	$C_{r\,rbb'}$ <50ps	287	
〃 2670	〃	〃	Si. E	35	30	100	200	125	0.1	35	40~240	12	2	10	−2	NF=2 dB (10V, 1 mA, 1 MHz)				>80*	C_{re} 2.2	$C_{r\,rbb'}$ <50ps	287	
★ 〃 2671	松下	RF	Si. EP	25	12	70	250	150	0.1	10	40~200	10	20							2500*	0.75		138C	
★ 〃 2672	日電	〃	Si. E	30	14	50	250	200	0.1	15	80	10	10	10	−10	$\|S_{21e}\|^2$=13.3dB (1GHz) NF=2.1dB (10V, 3mA, 0.5GHz)				3000*			314	
〃 2673	ローム	AF	Si. EP	40	32	1 A	600	125	0.5	20	180	3	100	5	−50					150*	15	$C_{r\,rbb'}$ 80ps	235	2SA881 とコンプリ
〃 2674	〃	RF. LN	〃	120	120	100	300	125	0.5	100	270	6	2	6	−2	NF=0.2dB (6 V, 0.1mA, 100Hz)				120*	3	$C_{r\,rbb'}$ 140ps	138	2SA1136 とコンプリ
〃 2675	〃	〃	〃	80	80	100	300	125	0.5	75	390	6	2	6	−2	NF=0.2dB (6 V, 0.1mA, 100Hz)				130*	3	$C_{r\,rbb'}$ 140ps	138	2SA1137 とコンプリ
〃 2676	日電	RF. LN	Si. E	80	80	10	500	125	0.1	70	400	6	1	6	−1	NF=1.5dB (5 V, 1 mA, 1 kHz)				200*	1.2	$C_{r\,rbb'}$ 85ps	278	
〃 2677	日立	RF. Conv. Mix. Osc	Si. P	30	30	100	625	125	1	18	100	12	2	12	−1					230*	1.8	40	138D	
〃 2678	〃	〃	〃	20	15	30	500	125	1	10	100	6	1	6	−6					300*	1.4	$C_{r\,rbb'}$ 24ps	138D	
〃 2679	〃	Osc	Si. EP	30	19	50	300	125	0.5	10	80	10	10	10	−10	P_{osc}=8 mW (V_{CB}=10V, I_C=10mA, f=930MHz)				1000*	1.2	$C_{r\,rbb'}$ 10ps	138D	
〃 2680	松下	RF	〃	40	25	30	200	125	10	40	>38	10	7	10	−5	G_{pe}=25dB (6 V, 7 mA, 58MHz)				550*	C_{re} 0.37		176	
〃 2681	日電	PA	Si. T	115	115	10A	100W (Tc=25°C)	150	50	80	140	2	1 A	2	−1A					80*	230		162	2SA1141 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	r_{bb} h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC2682	日電	PA	Si. E	180	180	100	8 W (Tc=25°C)	150	1	180	200	5	10	10	−20					160*	3.5	33*	225	
★ 〃 2683	松下																							
★ 〃 2684	〃	PA	Si. EP	36	16	600	10W (Tc=25°)	150	100	15	80	10	200	10	−100	P_o=0.95W, η=40% (V_{CC}=12.5V, f=940MHz, P_i=0.15W)				4000*	5		338	
★ 〃 2685	〃	〃	〃	36	16	2 A	20W (Tc=25°)	150	500	15	50	10	500	10	−500	P_o=5.5W, η=40% (V_{CC}=12.5dB, f=940MHz, P_i=0.8W)				2000*	45～55		374	
★ 〃 2686	〃	〃	〃	36	16	3 A	40W (Tc=25°)	150	1 mA	15	50	10	2 A	10	−1A	P_o=13W, η=40% (V_{CC}=12.5V, f=940MHz, P_i=4W)				1500*	80		374	
〃 2687	日電	PA	Si. T	300	300	200	1 W	150	0.1	200	120	10	10	30	−10					80	2.5	25	278	
〃 2688	〃	RF. PA	〃	300	300	200	10W (Tc=25°C)	150	0.1	200	40～250	10	10	30	−10					80*	Cre<3		225	
★ 〃 2689	〃	PA	〃	300	300	200	10W (Tc=25°C)	150	0.1	200	100	10	10	30	−10					80*	3	30	167	
〃 2690	〃	〃	Si. E	120	120	1.2A	20W (Tc=25°C)	150	50	110	150	5	300	5	−200					160*	19	15	225	○
〃 2691	三菱	RF. AF	Si. EP	20	20	50	200	125	0.1	15	250	6	1	6	−1					100*	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	175	
〃 2692	日電	PA	Si. E	28	14	200	5 W (Tc=25°C)	200	0.5	10	40	6	100	10	−100	P_o=450mW (V_{CC}=10V, f=2GHz, P_i=40mW)				4500*	1.1		207	
〃 2693	東芝	〃	〃	70	30	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	40	50	5	1 A			P_o=12W (PEP) (f=28MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=0.2W(PEP))							325	
〃 2694	三菱	〃	Si. EP	35	17	20A	140W (Tc=25°C)	175	5 mA	15	50	10	1 A			P_o=75W, η=70% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=15W)							303	各リード・フランジ間絶縁
〃 2695	〃	RF. PA	〃	35	17	10A	75W (Tc=25°C)	175	2 mA	15	50	10	1 A			P_o=32W, η=60% (f=520MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=9 W)							272A	
〃 2696																								
〃 2697																								
〃 2698																								
〃 2699																								
〃 2700	富士通	PA	Si. EP	45	40	1 A	12W (Tc=25°C)	175	200	20	50	5	500			P_o=6.5W, ηc=60% (f=470MHz, V_{CC}=18V, P_i=0.8W)					9	20	159	
〃 2701	〃	〃	〃	35	35	300	3.5W (Tc=25°C)	175	500	24	50	10	100			P_o=1.1W, ηc=45% (f=2.3GHz, V_{CC}=24V, P_i=0.3W)					<3	50	183A	
〃 2702	〃	〃	〃	35	35	500	6 W (Tc=25°C)	175	500	24	50	10	100			P_o=2.2W, ηc=40% (f=2.3GHz, V_{CC}=24V, P_i=0.7W)					<4	70	183A	
〃 2703	東芝	RF	Si. E	30	30	1 A	900	150	0.1	30	200	2	100	2	−100					150*	13	20	241	
★ 〃 2704	〃	〃	〃	150	150	50	10W (Tc=25°C)	150	0.1	150	150	5	10	10	−10					200*	1.8	50	342	
〃 2705	〃	〃	〃	150	150	50	800	150	0.1	150	160	5	10	10	−10					200*	1.8	70	241	2SA1145とコンプリ
〃 2706	〃	PA	〃	140	140	10A	100W (Tc=25°C)	150	50	140	120	5	1 A	10	−1A					90*	130	2*	179	
〃 2707	〃	〃	〃	180	180	15A	150W (Tc=25°C)	150	50	160	120	5	1 A	10	−1A					80*	200	2*	102	2SA1147とコンプリ
★ 〃 2708	〃																							
★ 〃 2709	〃																							
〃 2710	〃	AF	Si. E	35	30	800	300	125	0.1	30	100～320	1	100	5	−10					120*	13		287	2SA1150とコンプリ
〃 2711	〃	PA	〃	35	17	800	7.5W (Tc=25°C)	175	500	15	50	5	500			P_o=6 W (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=0.4W)							208	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC2712	東芝	RF. AF	Si. E	60	50	150	150	125	0.1	60	350	6	2	10	−1					150*	2	50	176	2SA1162とコンプリ
〃 2713	〃	〃	〃	120	120	100	150	125	0.1	120	350	6	2	10	−1	NF= 1 dB (6 V, 0.1mA, 100Hz)				100*	3	18	176	2SA1163とコンプリ
〃 2714	〃	RF	〃	40	30	20	100	125	0.5	40	100	6	1	6	−1					550*	1	$C_c r_{bb'}$ 15ps	176	
〃 2715	〃	〃	〃	35	30	50	150	125	0.1	35	100	12	2	10	−1					150*	2	$C_c r_{bb'}$ 30ps	176	
〃 2716	〃	〃	〃	35	30	100	150	125	0.1	35	100	12	2	10	−1					120*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 20ps	176	
〃 2717	〃	〃	Si. EP	30	25	50	300	125	0.1	30	40~240	12.5	12.5	12.5	−12.5	G_{pe}=28~36dB (V_{CE}=12.5V, I_C=12.5mA, f=45MHz)				>300*	0.8~2.0	$C_c r_{bb'}$ <25ps	138C	
〃 2718	日電	AF	Si. E	60	50	100	250	125	0.1	60	200	6	1	6	−10	NF<15dB (6 V, 0.1mA, f= 1 kHz)				250*	3		138	2SA1151とコンプリ
〃 2719	〃	RF. SW	〃	80	80	300	600	150	0.1	80	200	1	50	6	−10	t_{on}=50ns, t_{off}=560ns t_{stg}=480ns				140*	7		138	2SA1152とコンプリ
〃 2720	〃	〃	〃	60	40	500	600	150	0.1	40	150	1	150	10	−20	t_{on}<35ns, t_{off}<275ns t_{stg}<225ns				400*	3.5		138D	2SA1153とコンプリ
〃 2721	〃	〃	〃	60	60	700	1 W	150	0.1	60	200	1	100	6	−10	t_{on}=60ns, t_{off}=650ns t_{stg}=600ns				110*	13		278	2SA1154とコンプリ
〃 2722	サンケン	PA	Si. TMe	100	80	15A	150W (T_c=25°C)	150	1 mA	100	80	4	5 A	12	−500					20*	270	7	256	
★ 〃 2723	〃	SW	〃	450	400	15A	150W (T_c=25°C)	150	1 mA	450	20	4	5 A	12	−1A					30*	260	4.6	324	
〃 2724	三菱	RF	Si. E	30	25	30	200	125	1	25	35~180	6	1	6	−1	NF= 3 dB (6 V, 1 mA, 10.7MHz)				200*	2	$C_c r_{bb'}$ 20ps	175	
★ 〃 2725	〃	Diff.	〃	100	100	100	200/unit	125	0.1	100	600	6	1	6	−1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0 ΔV_{BE}<10mV				100*	2.5		283	2素子複合
★ 〃 2726	日立	RF	〃	15	12	20	200	125	1	12	100	4	2	4	−2	G_{pb}=16dB, NF= 4 dB (6 V, 2 mA, 900MHz)				1100*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	240A	
〃 2727	〃	RF. LN	〃	15	12	20	200	150	0.5	12	110	4	2	4	−2	G_{pe}=21dB, NF=2.3dB (6 V, 2 mA, 200MHz)				1000*	C_{re} 0.8	$C_c r_{bb'}$ 10ps	240C	フォワードAGC
★ 〃 2728	〃	Conv.	〃	15	10	50	200	125	1	12	100	4	5	4	−5	G_{pb}=14dB, NF= 6 dB (6 V, 5 mA, 900MHz)				2500*	1	$C_c r_{bb'}$ 12ps	240A	
〃 2729	〃	〃	〃	15	10	50	200	125	1	12	80	4	5	4	−5	G_{pe}=21dB, NF= 4 dB (6 V, 2 mA, 200MHz)				1300*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 10ps	240C	
〃 2730	〃	Osc.	〃	15	10	50	200	150	0.5	12	110	4	5	4	−5	V_{osc}=32mV (6 V, 6 mA, 930MHz)				1600*	0.96	$C_c r_{bb'}$ 15ps	240B	
〃 2731	〃	Conv.	〃	20	11	50	200	150	0.5	16	80	10	5	10	−5	G_{ce}=17dB, NF=9.5dB (10V, 3 mA, 900MHz)				3500*	1	$C_c r_{bb'}$ 9 ps	240A	
〃 2732	〃	〃	〃	30	25	20	150	150	0.5	10	60	10	3	10	−3	G_{cb}= 7 dB, NF=10dB (12V, 1 mA, 900MHz)				1000*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	176	
〃 2733	〃	〃	〃	30	20	50	150	150	0.5	10	120	10	10	10	−10	G_{ce}=21dB, NF= 4 dB (12V, 2 mA, 200MHz)				1000*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 12ps	176	
〃 2734	〃	〃	〃	20	11	50	150	150	0.5	10	90	10	10	10	−10	G_{ce}=15dB, NF= 9 dB (12V, 2 mA, 900MHz)				3500*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176	
〃 2735	〃	Osc.	〃	30	20	50	150	150	0.5	10	100	10	10	10	−10	V_{osc}=210mV (12V, 7mA, 300MHz)				1200*	0.85	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176	
〃 2736	〃	Conv.	〃	30	20	50	150	150	0.5	15	80	10	5	10	−5	G_{cb}=22.5dB, NF=10dB (12V, 2 mA, 900MHz)				2200*	0.6	$C_c r_{bb'}$ 11ps	176	
★ 〃 2737	日電	LN	〃	20	10	80	600	150	1	10	80	8	20	8	−20	$\|S_{21e}\|^2$=11dB, (1GHz) NF=1.2dB (1GHz, 5mA)				8000*	C_{re} 0.65		138C	
〃 2738	松下	SW	Si. TMe	500	400	2 A	25W (T_c=25°C)	150	100	500	>8	5	1 A	10	−200	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs				11*			268	
〃 2739	〃	〃	〃	500	400	7 A	40W (T_c=25°C)	150	100	500	>8	5	3 A	10	−500	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs				11*			268	
〃 2740	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	500	>8	5	5 A	10	−500	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs				11*			365	
〃 2741	富士通	PA	Si. EP	36	33	1 A	7 W (T_c=25°C)	175	100	12	50	2	500	12	−100	P_o=2.5W (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=50mW)				2000*	5	7*	169	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC2742	富士通																								
	〃 2743	〃	PA	Si. EP	36	33	5 A	30W (Tc=25°C)	175	400	12	50	2	2 A	12	−400	P_o=15W (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=1.5W)				1300*	20	2.5*	257		
	〃 2744	〃	〃	〃	36	33	1 A	7 W (Tc=25°C)	175	100	12	50	2	500	12	−100	P_o=2.5W (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=0.3W)				2000*	5	7*	169		
	〃 2745	〃	〃	〃	36	33	4 A	25W (Tc=25°C)	175	300	12	50	2	1.5A	12	−300	P_o=9 W (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=2 W)				1500*	15	3.5*	257		
	〃 2746	〃	〃	〃	36	33	5 A	30W (Tc=25°C)	175	400	12	50	2	2 A	12	−400	P_o=15W (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=5 W)				1300*	20	2.5*	257		
★	〃 2747	〃																								
★	〃 2748	三菱	Diff.	Si. E	30	25	30	200/unit	125	1	25	150	6	1	6	−1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8～1.0 ΔV_{BE}<10mV				200*	2	$C_c r_{bb'}$ 20ps	274B	2素子複合	
	〃 2749	日電	SW	Si. T	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	35	5	1 A			t_{on}<1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}<2.5μs							162		○
	〃 2750	〃	〃	〃	150	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	10	100	>30	5	5 A			t_{on}<1 μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							162		
	〃 2751	〃	〃	〃	500	400	15A	120W (Tc=25°C)	150	100	400	35	5	2 A			t_{on}<1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}<2.5μs							162		○
	〃 2752	〃	〃	〃	500	400	500	10W (Tc=25°C)	150	10	400	40	5	50			t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2.5μs							225		
	〃 2753	東芝	RF	Si. E	17	12	70	300	150	1	10	100	10	20	10	−20	NF=1.7dB (10V, 5 mA, 1 GHz)				5000*	0.85	30*	138C		
	〃 2754	〃	SW	〃	35	30	100	200	125	0.1	35	200	12	2	12	−10	t_{on}<60ns, t_f<140ns t_{stg}<800ns				400*	2	30	138	2SA1164とコンプリ	
	〃 2755	日電	RF	〃	30	30	20	150	125	0.1	20	120	10	3	10	−3	G_{pr}=23dB (10V, 3 mA, 200MHz)				600*	0.3		176		
	〃 2756	〃	Mix	〃	30	20	30	150	125	0.1	20	120	10	5	10	−5	G_{cc}=23dB (10V, 3 mA, 200MHz)				850*	0.35	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176		
	〃 2757	〃	Osc.	〃	30	15	50	150	125	0.1	12	120	10	5	10	−5	V_{osc}=110mV (10V, 5 mA, 220MHz)				1100*	1.3	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176		
	〃 2758	〃	RF	〃	30	25	20	150	125	0.1	25	120	10	3	10	−3	G_{pr}=17dB (10V, 3 mA, 900MHz)				1100*	0.6		176		
	〃 2759	〃	Mix	〃	30	14	50	150	125	0.1	15	100	10	5	10	−5	G_{cb}=12.5dB (10V, 5 mA, 900MHz)				2000*	1		176		
	〃 2760	富士通	PA	Si. EP	50	29	10A	90W (Tc=25°C)	175	800	20	50	5	6 A			P_o=34W (V_{CC}=21V, f=470MHz, P_i=5 W)							168		
★	〃 2761	サンケン	SW	Si. TMe	450	400	30A	200W (Tc=25°C)	150	100	450	>8	2	15A			t_r=0.8μs, t_f=0.4μs t_{stg}=2.5μs							102		
	〃 2762	日電	PA	Si. E	35	18	400	800	200	100	20	60	10	100			P_o=1.4W, η=80% (f=500MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=0.25W)					C_{re} 2.5		84B		
	〃 2763	〃	〃	〃	35	18	4 A	43W (Tc=25°C)	200	1.25mA	30	60	10	800			P_o=16W (f=500MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=4 W)							327		
★	〃 2764	〃																								
★	〃 2765	〃																								
★	〃 2766	〃	PA	Si. T	160	160	15A	150W (Tc=25°C)	150	50	150	150	5	2 A	5	−1A					60*	180	15	340		○
	〃 2767	富士電機	〃	Si. TP	250	200	5 A	40W (Tc=25°C)	150	10	250	40	5	1 A			t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2 μs							268		
	〃 2768	〃	SW	〃	250	200	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	250	40	5	1 A			t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2 μs							268		○
	〃 2769	〃	PA	〃	250	200	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	250	20～60	5	2 A			t_{on}<0.8μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2 μs							211		
	〃 2770	〃	SW	〃	600	600	100A	770W (Tc=25°C)	125	1 mA	600	>8	5	60A			t_{on}<4 μs, t_f<3 μs t_{stg}<8 μs							221		
	〃 2771	三菱	Diff	Si. E	60	60	100	250/unit.	125	0.2	25	100	3	1	6	−2	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8～1.0 ΔV_{BE}<10mV				140*	2	$C_c r_{bb'}$ 40ps	283	2素子複合	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC2772	三菱																								
★	〃 2773	サンケン	PA	Si.TMe	200	200	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	200	80	4	5 A	12	−500					20*	250	10	256		
★	〃 2774	〃	〃	〃	200	200	17A	200W (Tc=25°C)	150	100	200	70	4	8 A	12	−500					20*	300	9	256		
	〃 2775	日立	RF	Si. E	90	60	50	150	125	0.5	75	700	12	2	12	−2					200*	1.6	$C_c r_{bb'}$ 12ps	176		
	〃 2776	〃	〃	Si. P	30	20	30	100	150	0.5	20	110	6	1	6	−1	G_{pe}=17dB (6V, 1mA, 100MHz)				320*	1.1	560*	176		
★	〃 2777	東芝																								
	〃 2778	松下	RF	Si.EP	30	20	30	200	125	1	10	250	10	1	10	−1					230*	C_{re} 1.3	60	176		
★	〃 2779	日電																								
	〃 2780	〃	AF	Si. E	140	140	50	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	140	200	10	10	10	−10					120*	2.3		336	2SA1173とコンプリ	
	〃 2781	富士通	Osc	Si.EP	35	35	500	6 W (Tc=25°C)	175	500	24	50	10	100			P_{out}=0.9W (f=2.3GHz, V_{CE}=18V, I_C=150mA)					<5		183C		
	〃 2782	東芝	PA	Si. E	36	16	20A	220W (Tc=25°C)	175	7 mA	15	70	5	10A			P_o=90W (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=18W)							192		
	〃 2783	〃	〃	〃	36	16	8 A	150W (Tc=25°C)	175	8 mA	15	70	5	5 A			P_o=45W (f=470MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=13W)							192		
	〃 2784	日電	RF. LN	〃	120	120	50	300	125	0.1	50	400	6	1	6	−1	NF=1dB (6V, 1mA, 1kHz)				100*	1.6	$C_c r_{bb'}$ 130ps	42		
	〃 2785	〃	AF	〃	60	50	100	300	125	0.1	60	200	6	1	6	−10	NF<15dB (6V, 0.1mA, f=1kHz)				250*	3		42	2SA1175とコンプリ	
	〃 2786	〃	RF. Mix Conv. Osc	〃	30	20	20	300	125	0.1	30	90	6	1	6	−1	G_{pe}=22dB, NF=3dB (f=100MHz)				600*	1	$C_c r_{bb'}$ 12ps	42		
	〃 2787	〃	RF. IF. Mix Conv. Osc	〃	50	30	30	300	125	0.1	50	90	6	1	6	−1	NF=2dB (f=1MHz)				250*	1.9	$C_c r_{bb'}$ 10ps	42		
★	〃 2788	新電元	SW	Si. T	500	400	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	500	20	2	4 A	10	−1A	t_{on}=0.7μs, t_f=0.4μs t_{stg}=2.4μs				20*			197	T8Y40F1	
★	〃 2789	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	20	2	5 A	10	−1A	t_{on}=0.7μs, t_f=0.5μs t_{stg}=2.4μs				20*			197	T10Y40F1	
	〃 2790	東芝	〃	〃	850	800	2 A	80W (Tc=25°C)	150	100	800	25	5	500			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs							102		○
	〃 2791	〃	〃	〃	900	800	5 A	100W (Tc=25°C)	150	100	800	20	5	3 A			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3.5μs							102		
	〃 2792	〃	〃	〃	850	800	2 A	80W (Tc=25°C)	150	100	800	25	5	500			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs							203		
	〃 2793	〃	〃	〃	900	800	5 A	100W (Tc=25°C)	150	100	800	20	5	3 A			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3.5μs							125		
★	〃 2794	〃	PA	Si. E	60	60	2 A	25W (Tc=25°C)	150	1	60	100	2	150	2	−150					40*	45	50	342		
★	〃 2795																									
	〃 2796	三菱	PA	Si. EP	45	35	6 A	75W (Tc=25°C)	175	2 mA	75	50	25	200			P_o=44W (V_{CC}=24V, f=470MHz, P_i=10W)							303		
	〃 2797	〃	〃	〃	45	35	1 A	10W (Tc=25°C)	150	400	25	50	25	100			P_o=6W (V_{CC}=24V, f=770MHz, P_i=1W)							187		
	〃 2798	〃	〃	〃	45	35	2 A	30W (Tc=25°C)	175	1 mA	25	50	25	100			P_o=14W (V_{CC}=24V, f=770MHz, P_i=3W)							187		
	〃 2799	〃	〃	〃	45	35	4 A	50W (Tc=25°C)	175	1.5mA	25	50	25	200			P_o=27W (V_{CC}=24V, f=770MHz, P_i=8W)							187	エミッタ・スタッド間接続	
	〃 2800	〃	〃	〃	45	35	6 A	75W (Tc=25°C)	175	2 mA	25	50	25	200			P_o=42W (V_{CC}=24V, f=770MHz, P_i=15W)							303		
★	〃 2801	〃																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC2802	日電	PA	Si. T	300	300	200	10W (Tc=25°C)	150	0.1	200	40~250	10	10	30	−10					80*	< 3		185	
〃 2803	松下	RF	Si. EP	150	150	1 A	20W (Tc=25°C)	150	5	100	160	10	150	10	−50					200*	20	100	222	2SA1178とコンプリ
〃 2804	東芝	〃	Si. P	25	20	20	200	125	0.1	10	100	10	2	10	−2					900*	0.85	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	347A	
〃 2805	〃	〃	Si. E	30	15	50	200	125	0.1	15	100	3	8	10	−8					1000*	1	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	347B	
〃 2806	〃	〃	〃	30	15	50	200	125	0.1	15	100	3	8	10	−8					900*	1	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	347B	
★ 〃 2807	富士通																							
〃 2808	ローム	RF. AF	Si. EP	160	100	50	500	125	0.5	120	390	6	2	12	−2					140*	7.5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	138	
★ 〃 2809	サンケン	PA	Si.TMe	300	300	2 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	80	4	300	10	−100					20*	45	14	324	
〃 2810	〃	SW	Si. TP	500	400	7 A	50W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	3 A			t_{on}<0.7μs, t_f<0.7μs t_{stg}<2.5μs							298	
〃 2811	日電	Osc.	Si. E	45	23	1 A	17.5W (Tc=25°C)	200	150	30	60	10	500	10	−300	P_{osc}=1.4W (f=950MHz×2, V_{CC}=18V, I_C=350mA)				1200*	Cre 6.5		157	
〃 2812	三洋	RF	Si. EP	55	50	150	200	125	0.1	35	400	6	1	6	−1					100*	3	$C_c r_{bb'}$ 250ps	176	
〃 2813	〃	〃	〃	25	20	30	150	125	0.1	10	150	6	1	6	−4					600*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 18ps	176	
〃 2814	〃	〃	〃	30	20	30	150	125	0.1	10	150	6	1	6	−1					320*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 12ps	176	
〃 2815	日立	SW	Si. T	300	250	5 A	40W (Tc=25°C)	150	20	250	40	5	2.5A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							268	
〃 2816	〃	〃	〃	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	50	400	20	5	2.5A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							268	
★ 〃 2817	〃	〃	〃	300	250	10A	80W (Tc=25°C)	150	20	250	40	5	5 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2 μs							332	
〃 2818	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	50	400	20	5	5 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							102	
〃 2819	〃	〃	〃	500	400	15A	100W (Tc=25°C)	150	50	400	20	5	7.5A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							102	
〃 2820	〃	〃	〃	400	400	20A	125W (Tc=25°C)	150	50	400	20	5	10A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							102	
〃 2821	〃	RF. AF	Si. E	20	10	50	150	150	1	6	500	1	10	12	−2					200*	1.8	100	176	
〃 2822	日立	SW	〃	75	50	800	360	200	0.01	60	200	10	150	20	−20	t_{on}<35ns, t_{off}<300ns t_{stg}<290ns				350*	4		49C	
★ 〃 2823	東芝	PA	〃	120	120	7 A	70W (Tc=25°C)	150	50	120	15000	5	1 A	5	−1A					60*	90	10	203	ダーリントン
★ 〃 2824	〃	RF	〃	120	120	1 A	15W (Tc=25°C)	150	0.1	120	150	5	100	5	−100					120*	15	3*	342	2SA1184とコンプリ
〃 2825	サンケン	PA	Si.TMe	80	60	6 A	70W (Tc=25°C)	150	100	80	800	4	1 A	10	−500					35*	140	25	324	
〃 2826	新電元	SW	Si. T	500	400	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	500	13	2	1.5A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs				20*			268	
〃 2827	〃	〃	〃	500	400	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	500	13	2	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs				20*			268	
★ 〃 2828	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	13	2	5 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs							197	
〃 2829	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	13	2	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs				20*			102	
〃 2830	〃	〃	〃	500	400	20A	200W (Tc=25°C)	150	100	500	13	2	10A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs				20*			103	
〃 2831	松下	〃	〃	800	500	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	100	800	> 8	5	1 A	10	−200	t_{on}< 1 μs, t_f<1 μs t_{stg}< 3 μs				2.5*			268	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SC2832	松下	SW	Si. T	800	500	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	800	> 8	5	3 A	10	−500	t_{on} < 1 μs, t_f < 1 μs t_{stg} < 3 μs				3 *			268		○
	〃 2833	〃	〃	Si.TMe	800	500	5 A	100W (Tc=25°C)	150	100	800	> 8	5	3 A	10	−500	t_{on} < 1 μs, t_f < 1 μs t_{stg} < 3 μs				3 *			365		○
	〃 2834	〃	〃	Si. T	800	500	7 A	100W (Tc=25°C)	150	100	800	> 8	5	5 A	10	−500	t_{on} < 1 μs, t_f < 1 μs t_{stg} < 2.5μs				3.5 *			365		○
★	〃 2835	日電																								
★	〃 2836	〃																								
	〃 2837	サンケン	PA	Si. EP	150	150	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	150	60	4	3 A	12	−1A					70 *	60	30	324	2SA1186とコンプリ	
★	〃 2838	〃	〃	〃	150	150	12A	120W (Tc=25°C)	150	100	150	60	4	3 A	12	−1A					70 *	60	30	256		
	〃 2839	三洋	RF	〃	30	20	30	150	125	0.1	10	200	6	1	6	−1					320 *	1.5	$C_c r_{bb'}$ 12ps	92		
	〃 2840	〃	〃	〃	25	20	30	150	125	0.1	10	200	6	1	6	−4					600 *	1.1	$C_c r_{bb'}$ 15ps	92		
	〃 2841	松下	PA. SW	Si.TMe	500	400	7 A	80W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	3 A			t_{on} < 1 μs, t_f < 1 μs t_{stg} < 3 μs							365		
★	〃 2842																									
★	〃 2843																									
	〃 2844	松下	RF	Si. EP	25	12	70	250	125	0.1	15	120	10	20	10	−20					4500 *	0.75	15	337A		
	〃 2845	〃	RF. LN	〃	25	12	70	200	125	0.1	15	40~200	10	20	10	−20	$\|S_{21e}\|^2$=10.5dB, NF=1.8dB (f=800MHz) (I_C=5mA)				4500 *	1		176		
★	〃 2846																									
★	〃 2847	松下	RF	Si. P	30	20	20	150	125	100	30	>20	10	2	10	− 2	G_{pe}=18dB (V_{CC}=12V, V_{AGC}= 3 V, f=200MHz)				>600 *	0.5		176	フォワードAGC	
★	〃 2848																									
★	〃 2849																									
★	〃 2850	日電	PA	Si. E	35	18	3 A	35W (Tc=25°C)	200	300	20	60	10	500			P_o=11W (V_{CC}=13.5V, f=860MHz, P_i=4W)					C_{rc} 14		326		
	〃 2851	松下	〃	Si. EP	36	16	300	1 W	150	10	20	50	13.5	100	10	−100	P_o=0.9W (V_{CC}=13.5V, f=175MHz, P_i=30mW)				2000 *	4	20	294		
	〃 2852	〃	〃	〃	36	16	500	2.5W (Tc=25°C)	175	1	20	70	13.5	100	10	−30	P_o= 1 W (V_{CC}=13.5V, f=470MHz, P_i=0.1W)				1800 *	4	21 *	84B		
	〃 2853	日立	RF. AF	Si. E	90	90	100	400	150	0.1	70	450	12	2	6	−10					310 *	3	35	138	2SA1188とコンプリ	
	〃 2854	〃	〃	〃	120	120	100	400	150	0.1	70	400	12	2	6	−10					310 *	3	30	138	2SA1189とコンプリ	
	〃 2855	〃	RF. LN	〃	90	90	100	400	150	0.1	70	450	12	2	6	−10	NF=0.15dB (6 V, 10mA, 1 kHz)				310 *	3	30	138	2SA1190とコンプリ	
	〃 2856	〃	〃	〃	120	120	100	400	150	0.1	70	400	12	2	6	−10	NF=0.15dB (6 V, 10mA, 1 kHz)				310 *	3	30	138	2SA1191とコンプリ	
	〃 2857	三洋	RF	Si.TP	180	180	50	500	150	1	180	100	10	10	30	−10					130 *	2.8	$C_c r_{bb'}$ 50ps	138		
★	〃 2858	日立	SW	Si. T	500	400	8 A	65W (Tc=25°C)	150	100	400	20	5	4 A			t_{on} < 1 μs, t_f < 1 μs t_{stg} < 2.5μs					30		332		
	〃 2859	東芝	AF. RF	Si. E	35	30	500	150	125	0.1	35	120	1	100	6	−20					300 *	7	20	176	2SA1182とコンプリ	
★	〃 2860	松下	RF. AF	Si. EP	30	20	15	150	125	0.1	10	65~260	6	1	6	− 1					650 *	C_{rc} 0.8		276		
★	〃 2861	ソニー																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★ 2SC2862	ソニー																							
★ 〃 2863	〃																							
★ 〃 2864	〃																							
〃 2865	新電元	SW	Si. E	250	200	20A	200W (Tc=25°C)	150	100	250	18	2	10A			t_{on}<0.9μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs							103	○
★ 〃 2866	松下																							
〃 2867	日立	SW	Si. T	300	200	10A	50W (Tc=25°C)	150	20	250	100	5	4 A			t_{on}< 1 μs, t_{off}<1.5μs t_{stg}<1.5μs							268	
★ 〃 2868	東芝	AF. RF	Si. E	80	80	100	400	125	0.1	80	400	6	2	10	−2					200*	2.5	60	138	2SA1158 とコンプリ
〃 2869	日電	LN	〃	20	10	80	400	150	1	10	80	8	20	8	−20	$\|S_{21e}\|^2$=13dB, NF=1.2dB (f=1 GHz) (1 GHz, 5 mA)				8000*	C_{re} 0.7		210B	
〃 2870	日立	RF	Si. T	300	300	100	10W (Tc=25°C)	150	1	250	90	20	20	20	−20					80*	3	10*	245	
〃 2871	〃	PA	Si. E	60	60	1 A	8 W (Tc=25°C)	150	10	60	40000	10	500			t_{on}<0.2μs, t_{off}< 5 μs t_{stg}< 4 μs							245	ダーリントン
〃 2872	ローム	AF. RF	Si. EP	50	40	700	400	125	0.5	30	270	6	10	6	−10					100*	10	$C_c r_{bb'}$ 200ps	138	2SA1199 とコンプリ
〃 2873	東芝	RF	Si. E	50	50	2 A	500	150	1	50	130	2	500	2	−500					120*	30	7*	336	2SA1213 とコンプリ
★ 〃 2874	〃																							
〃 2875	〃	RF. SW	Si. E	35	30	100	200	125	0.1	35	200	12	2	12	−10	t_{on}<100ns, t_f<200ns t_{stg}< 1 μs				400*	2	60	287	
〃 2876	〃	RF	〃	15	7.5	80	200	125	0.1	10	80	3	50	5	−30	NF=2.3dB (5 V, 10mA, 1 GHz)				7000*	1.25	47*	347C	
★ 〃 2877	〃	〃	〃	40	40	3 A	10W (Tc=25°C)	150	0.1	40	150	2	500	2	−500					100*	35	10	342	2SA1217 とコンプリ
〃 2878	〃	RF. SW	〃	50	20	300	400	125	0.1	50	600	2	4	2	−4	t_{on}<300ns, t_f<200ns t_{stg}<800ns				30*	4.8	40	138	
〃 2879	〃	PA	〃	45	18	25A	250W (Tc=25°C)	175	8 mA	15	50	5	10A			P_o=120W (PEP) (f=28MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=10W (PEP))							281	
〃 2880	〃	RF. AF	Si. T	200	150	50	500	150	0.1	200	100	5	10	30	−10					120*	3.5	25	336	2SA1200 とコンプリ
〃 2881	〃	〃	Si. E	120	120	800	500	150	0.1	120	140	5	100	5	−100					120*	12	6*	336	2SA1201 とコンプリ
〃 2882	〃	〃	〃	80	80	400	500	150	0.1	80	130	5	50	2	−50					100*	10	5	336	2SA1202 とコンプリ
〃 2883	〃	〃	〃	30	30	1.5A	500	150	0.1	30	180	2	500	2	−500					120*	30	8*	336	2SA1203 とコンプリ
〃 2884	〃	〃	〃	35	30	800	500	150	0.1	35	130	1	100	5	−10					120*	13	25	336	2SA1204 とコンプリ
〃 2885	日電	SW	〃	330	200	2 A	15W (Tc=25°C)	150	10	250	60	5	100			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							186	
〃 2886	〃	PA	〃	55	32	750	13W (Tc=25°C)	200	250	30	60	10	200			P_o= 5 W (f=175MHz, V_{CC}=28V, P_i=63mW)							129	
〃 2887	〃	〃	〃	55	32	1.5A	22W (Tc=25°C)	200	500	30	60	10	400			P_o=14W (V_{CC}=28V, f=175MHz, P_i=0.4W)							129	
〃 2888	〃	〃	〃	55	32	3 A	44W (Tc=25°C)	200	1 mA	30	60	10	800			P_o=28W (V_{CC}=28V, f=175MHz, P_i=1.6W)							43	
〃 2889	〃	〃	〃	55	32	6 A	83W (Tc=25°C)	200	2 mA	30	60	10	1.5A			P_o=40W (V_{CC}=28V, f=175MHz, P_i= 5 W)							348	
〃 2890	〃	〃	〃	55	32	12A	140W (Tc=25°C)	200	4 mA	30	60	10	2 A			P_o=84W (V_{CC}=28V, f=175MHz, P_i=10W)							233	
〃 2891	〃	〃	〃	55	32	15A	175W (Tc=25°C)	200	6 mA	30	60	10	3 A			P_o=112W (V_{CC}=28V, f=175MHz, P_i=16W)							233	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC2892	日電	PA	Si. E	55	32	750	13W (Tc=25°C)	200	250	30	60	10	200			P_o = 4 W (f=400MHz, V_{CC}=28V, P_i=0.1W)							129	
〃 2893	〃	〃	〃	55	32	1.5A	22W (Tc=25°C)	200	500	30	60	10	400			P_o = 10W (f=400MHz, V_{CC}=28V, P_i=0.63W)							129	
〃 2894	〃	〃	〃	55	32	3 A	44W (Tc=25°C)	200	1 mA	30	60	10	800			P_o = 22W (V_{CC}=28V, f=400MHz, P_i=3.2W)							43	
〃 2895	〃	〃	〃	55	32	6 A	83W (Tc=25°C)	200	2 mA	30	60	10	1.5A			P_o = 40W (V_{CC}=28V, f=400MHz, P_i= 4 W)							368	
〃 2896	〃	〃	〃	55	32	12A	140W (Tc=25°C)	200	4 mA	30	60	10	2 A			P_o = 63W (V_{CC}=28V, f=400MHz, P_i=10W)							368	
〃 2897	〃	〃	〃	55	32	15A	175W (Tc=25°C)	200	6 mA	30	60	10	3 A			P_o = 100W (V_{CC}=28V, f=400MHz, P_i=20W)							368	
〃 2898	日立	SW	Si. T	500	400	8 A	50W (Tc=25°C)	150	50	400	20	5	4 A			t_{on}< 0.8μs, t_f<0.8μs t_{stg}< 2 μs							268	
〃 2899	〃	〃	〃	500	400	500	10W (Tc=25°C)	150	20	400	20	5	250			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							160	
★ 〃 2900	サンケン	PA	Si. TMe	350	300	4 A	90W (Tc=25°C)	150	100	350	70	5	1 A	12	−100					10 *	140	10	324	
〃 2901	日電	SW	Si. E	40	15	200	600	150	0.1	20	90	1	10	10	−10	t_{on}<12ns, t_{off}<18ns t_{stg}<13ns				750 *	1.8		138D	2SA1206 とコンプリ
〃 2902	オリジン	〃	Si. T	800	400	15A	150W (Tc=25°C)	150	50	640	15	5	7.5A			t_{on}<1.5μs, t_f< 1 μs t_{stg}<3.5μs							102	
〃 2903	〃	〃	〃	800	400	25A	200W (Tc=25°C)	150	50	640	15	5	10A			t_{on}<1.5μs, t_f< 1 μs t_{stg}<3.5μs							102	
〃 2904	三菱	PA	Si. EP	50	20	22A	200W (Tc=25°C)	175	5 mA	15	50	10	1 A			P_o = 110W (V_{CC}=12.5V, f=30MHz, P_i= 7 W)							303	
〃 2905	〃	〃	〃	35	17	15A	120W (Tc=25°C)	175	2 mA	15	50	10	1 A			P_o = 50W (V_{CC}=13.5V, f=520MHz, P_i=15W)							303	
〃 2906	日電	〃	Si. E	25	12	2.2A	22W (Tc=25°C)	200	300	20	60	7	300			P_o = 6.3W (V_{CC}=7.2V, f=500MHz, P_i=2.3W)							326	
〃 2907	富士電機	SW	Si. TP	400	350	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	400	150	5	1 A			t_{on}< 2 μs, t_f<1.5μs t_{stg}< 4 μs							268	
〃 2908	日電	〃	Si. E	200	100	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	100	160	5	300			t_{on}<0.5μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							162	
〃 2909	三洋	RF. AF	Si. EP	180	160	70	600	150	0.1	80	200	5	10	10	−10					150 *	2	$C_c r_{bb'}$ 40ps	138	2SA1207 とコンプリ
〃 2910	〃	AF. SW	〃	180	160	70	900	150	0.1	80	100~400	5	10	10	−10	t_{on}=0.1μs, t_f=0.2μs t_{stg}= 1 μs				150 *	2		294	2SA1208 とコンプリ
〃 2911	〃	〃	〃	180	160	140	10W (Tc=25°C)	150	0.1	80	100~400	5	10	10	−10	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_{stg}=1.5μs				150 *	3		296	2SA1209 とコンプリ
〃 2912	〃	〃	〃	200	200	140	10W (Tc=25°C)	150	0.1	160	100~400	5	10	10	−10	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_{stg}=1.5μs				150 *	3		296	2SA1210 とコンプリ
〃 2913	東芝	SW	Si. T	500	400	8 A	40W (Tc=25°C)	150	100	400	22	5	3 A			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							134	
〃 2914	〃	〃	〃	500	400	10A	120W (Tc=25°C)	150	100	400	20	5	5 A			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							102	
〃 2915	日電	PA	Si. E	35	18	20A	175W (Tc=25°C)	200	4 mA	20	60	10	2 A			P_o = 48.2dBm (V_{CC}=13.5V, f=500MHz, P_i=44dBm)					120 *		368	
〃 2916																								
〃 2917	日電	PA	Si. E	35	18	20A	175W (Tc=25°C)	200	4 mA	20	80	10	2 A			P_o = 49.2dBm (V_{CC}=13.5V, f=500MHz, P_i=42dBm)					120 *		368	
★ 〃 2918	〃	〃	〃	35	16	5 A	63W (Tc=25°C)	200	1 mA	20	50	10	500			P_o = 21W (f=860MHz, V_{CC}=13.5V, P_i= 5 W)							327	
★ 〃 2919	〃																							
〃 2920	富士通	SW	Si. EP	450	400	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	450	13	2	10A	10	−2A	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 3 μs				30 *	240		102	
〃 2921	サンケン	PA	〃	160	160	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	160	80	4	5 A	12	−2A					60 *	200	15	256	2SA1215 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC2922	サンケン	PA	Si. EP	180	180	17A	200W (Tc=25°C)	150	100	180	70	4	8 A	12	−2A					50*	250	10	256	2SA1216とコンプリ
〃 2923	松下	RF	Si. TP	300	300	100	1.5W	150	1	200	120	50	5	30	−20					140*	2.4	40	161	
〃 2924	〃	〃	〃	300	300	100	10W (Tc=25°C)	150	1	300	120	50	5	30	−20					140*	2.4	45	361	
〃 2925	〃	〃	Si. EP	60	50	700	750	150	1	20	1000	10	150	10	−50					250*	11	35	138	
〃 2926	ローム	〃	〃	30	19	50	300	125	0.5	20	120	10	5	5	−10					1100	1.2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138	
★ 〃 2927	日立	〃	Si. T	300	300	200	10W (Tc=25°C)	150	0.1	250	120	10	50	20	−30					80*	4	20*	234	
〃 2928	〃	SW	〃	1500	800	5 A	80W (Tc=25°C)	150	100	1200	20	5	500			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							102	
〃 2929	富士電機	〃	Si. TP	450	400	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	450	20	5	500			t_{on}<1.5μs, t_f<0.8μs t_{stg}< 2 μs							268	
〃 2930	〃	〃	〃	500	400	30A	200W (Tc=25°C)	150	1 mA	500	20	5	10A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							103	
〃 2931	三菱	PA	Si. EP	35	17	600	10W (Tc=25°C)	175	1 mA	15	30	10	100			P_o=1.7W (V_{CC}=12.5V, f=900MHz, P_i=0.3W)							272A	
〃 2932	〃	〃	〃	35	17	2 A	20W (Tc=25°C)	175	2 mA	15	30	10	100			P_o= 7 W (V_{CC}=12.5V, f=900MHz, P_i= 1 W)							272B	
〃 2933	〃	〃	〃	35	17	4 A	40W (Tc=25°C)	175	2 mA	15	30	10	200			P_o=16W (V_{CC}=12.5V, f=900MHz, P_i= 3 W)							272B	
〃 2934	日立	RF	Si. T	300	300	200	12.5W (Tc=25°C)	150	0.1	250	120	10	50	20	−30					80*	4	20*	160	
★ 〃 2935	〃	〃	〃	300	300	200	15W (Tc=25°C)	150	0.1	250	100	10	50	20	−30					80*	6	20*	160	
〃 2936	〃	SW	〃	500	400	30A	150W (Tc=25°C)	150	200	400	20	5	15A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							103	
〃 2937	新電元	〃	〃	500	400	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	500	20	2	4 A	10	−1A	t_{on}< 1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}< 3 μs				20*			119	T8W40F1
〃 2938	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	20	2	5 A	10	−1A	t_{on}< 1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}< 3 μs				20*			119	T10W40F1
〃 2939	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	13	2	5 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs							119	
〃 2940	〃	〃	Si. TP	230	230	30A	300W (Tc=25°C)	150	100	230	20	0.5	30A			t_{on}<0.9μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.6μs,							266	
〃 2941	日電	PA	Si. T	25	16	220	5.5W (Tc=25°C)	200	0.5	15	20~200	8	100	8	−100	P_{osc}=25dBm (12V, 120mA, 7.5GHz)				6000*	1		311	
〃 2942	サンケン	SW	Si. TMe	230	230	50A	200W (Tc=25°C)	150	100	230	25	0.5	30A			t_{on}<1.2μs, t_{off}< 2 μs t_{stg}<1.8μs							230	
★ 〃 2943	ソニー	〃	Si. EP	390	250	15A	80W (Tc=25°C)	120	100	350	40	2	1 A	3	−1A	t_d<50μs, t_{sg}<1.25μs t_{on}<550μs, t_f<450μs				70*	160		350	
〃 2944	富士電機	SW	Si. TP	250	200	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	250	40	5	2 A			t_{on}<0.8μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs							220	
★ 〃 2945																								
〃 2946	日電	SW	Si. E	330	200	2 A	15W (Tc=25°C)	150	10	250	60	5	100			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							186	
★ 〃 2947	〃	AF	〃	60	50	100	250	150	0.0	60	200	6	1	6	−10	NF<15dB (6 V, 0.1mA, 1 kHz)				250*	3		42	2SA1219とコンプリ
★ 〃 2948	日立	SW	Si. T	500	400	50A	300W (Tc=25°C)	150	200	400	20	5	25A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							351	
〃 2949	日電	PA	Si. E	25	16	110	2.75W (Tc=25°C)	200	0.25	15	20~200	8	50	8	−50	P_{osc}=21.5dBm (12V, 80mA, 7.5GHz)				6500*	0.65		311	NE243187
〃 2950	〃	〃	〃	25	16	220	5.5W (Tc=25°C)	200	0.5	15	20~200	8	100	8	−100	P_{osc}=25dBm (12V, 120mA, 7.5GHz)				6000*	1		311	NE243287
〃 2951	〃	〃	〃	25	16	440	9.7W (Tc=25°C)	200	1	15	20~200	8	200	8	−200	P_{osc}=28dBm (12V, 200mA, 7.5GHz)				5500*	2.9		367	NE243499

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC2952	日電	RF	Si. E	30	20	250	5 W (Tc=25°C)	200	10	20	80	10	80	10	−60	|S21e|²=10dB (0.5GHz) NF=3.5dB (1 GHz)				2500*			85B	
〃 2953	〃	PA	〃	30	20	250	5 W (Tc=25°C)	200	10	20	80	10	80			|S21e|²=13.5dB (15V, 100mA, 500MHz)					1.8		129	
〃 2954	〃	RF	〃	35	18	150	400	150	0.5	20	100	10	50	Gpe=22dB (100V, 50mA, 200MHz)		NF=2.4dB (10V, 30mA, 200MHz)							336	
〃 2955	〃	〃	〃	15	10	5	50	150	0.1	5	100	1	0.25	1	−1	|S21e|²=7 dB (1 GHz) NF=3 dB (1 V, 0.5mA, 1 GHz)				4000*			314	
〃 2956	〃	PA	〃	45	20	600	10.9W (Tc=25°C)	200	250	30	40	5	100			Po=1.6W (VCC=15V, f=2.3GHz, Pi=0.36W)							213	
〃 2957	〃	〃	〃	45	20	1.2A	17.5W (Tc=25°C)	200	500	30	40	5	200			Po=2.8W (VCC=15V, f=2.3GHz, Pi=0.8W)							213	
〃 2958	〃	RF. PA	〃	160	140	500	1 W	150	0.2	100	200	2	100	10	−20					50*	15	15	278	
〃 2959	〃	〃	〃	160	160	500	1 W	150	0.2	100	200	2	100	10	−20					50*	15	15	278	
〃 2960	三洋	SW	Si. EP	60	50	150	250	150	0.1	40	240	6	1	6	−1	tr<130μs, tf<220μs tstg<450μs				100*	2.7		92	2SA1481 とコンプリ
〃 2961	富士電機	SW	Si. TP	400	300	10A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	400	17	5	4 A			ton<0.4μs, tf<0.4μs tstg<1.5μs							211	
〃 2962	〃	〃	〃	700	600	5 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	700	15	5	1 A			ton<0.5μs, tf<0.5μs tstg<2.5μs							211	
〃 2963	新電元	〃	〃	70	60	3 A	40W (Tc=25°C)	150	10	70	150	1	1 A			ton<0.5μs, tf<0.7μs tstg<3.5μs							268	
〃 2964	富士通	〃	Si. EP	600	400	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	500	8.5	5	10A	10	−2A	tr<0.5μs, tf<0.3μs tstg<1 μs				28*	230		102	
〃 2965	〃	〃	〃	600	450	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	500	8.5	5	10A	10	−2A	tr<0.5μs, tf<0.3μs tstg<1 μs				28*	230		102	
〃 2966	日電	〃	Si. EMe	225	225	40A	200W (Tc=25°C)	150	100	225	15	0.5	30A			ton<1 μs, toff<2 μs tstg<1.95μs							266	
★ 〃 2967	〃	RF. Mix Conv. Osc	Si. E	30	20	20	200	125	0.1	30	90	6	1	6	−1	Gpe=22dB, NF=3 dB (f=100MHz)				600*	1	Cc rbb' 12ps	42	
★ 〃 2968	〃	RF. IF. Mix Conv. Osc	〃	50	30	30	200	125	0.1	50	90	6	1	6	−1	NF=2 dB (f=1 MHz)				250*	1.9	Cc rbb' 10ps	42	
〃 2969	富士通	RF	Si. EP	36	33	4 A	30W (Tc=25°C)	175	400	12	50	2	3 A			Po=15W (f=470MHz, VCC=12.5V, Pi=5 W)					27		257	
〃 2970	オリジン	SW	Si. T	300	200	5 A	40W (Tc=25°C)	150	30	200	15	5	2 A			ton<1.5μs, tf<1 μs tstg<3.5μs							100	
〃 2971	〃	〃	〃	300	200	10A	100W (Tc=25°C)	150	30	200	15	5	5 A			ton<1.5μs, tf<1 μs tstg<3.5μs							102	
〃 2972	〃	〃	〃	300	200	15A	150W (Tc=25°C)	150	30	200	15	5	7.5A			ton<1.5μs, tf<1 μs tstg<3.5μs							102	
〃 2973	〃	〃	〃	300	200	40A	200W (Tc=25°C)	150	30	200	15	5	15A			ton<1.5μs, tf<1 μs tstg<3.5μs							266	
〃 2974	〃	〃	〃	300	200	70A	300W (Tc=25°C)	150	50	200	15	5	29A			ton<1.5μs, tf<1 μs tstg<3.5μs							121	
〃 2975	〃	〃	〃	800	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	30	640	15	5	2 A			ton<1.5μs, tf<1 μs tstg<3.5μs							100	
〃 2976	〃	〃	〃	800	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	30	640	15	5	5 A			ton<1.5μs, tf<1 μs tstg<3.5μs							102	
〃 2977	〃	〃	〃	800	400	30A	200W (Tc=25°C)	150	50	640	15	5	10A			ton<1.5μs, tf<1 μs tstg<3.5μs							266	
〃 2978	〃	〃	〃	800	400	50A	200W (Tc=25°C)	150	50	640	15	5	29A			ton<1.5μs, tf<1 μs tstg<3.5μs							121	
〃 2979	日立	〃	〃	900	800	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	750	20	5	300			ton<1 μs, tf<1 μs tstg<3 μs							268	
〃 2980	〃	〃	〃	900	800	5 A	80W (Tc=25°C)	150	100	750	20	5	500			ton<1 μs, tf<1 μs tstg<3 μs							332	
〃 2981	〃	〃	〃	900	800	8 A	100W (Tc=25°C)	150	100	750	20	5	800			ton<1 μs, tf<1 μs tstg<3 μs							102	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ab} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC2982	東芝	RF	Si. E	30	10	2 A	500	150	0.1	30	370	1	500	1	−500					150*	27	10	336	
〃 2983	〃	〃	〃	160	160	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	120	120	5	100	10	−100					100*	25	4*	344	2SA1225とコンプリ
〃 2984	日電	PA	〃	45	45	6 A	70W (Tc=25°C)	200	4.5mA	30	50	10	4.5A			P_o=25W (V_{CC}=18V, f=89MHz, P_i=5 W)					270		352	
〃 2985	〃	〃	〃	45	23	2 A	30W (Tc=25°C)	200	1 mA	18	60	10	500			P_o=7.9W (V_{CC}=18V, f=89MHz, P_i=2.5W)					11		184	
〃 2986	東芝	〃	〃	40	30	50	300	125	0.1	40	140	6	1	6	−1					350*	1.6	15	138	
〃 2987	日電	〃	Si. E	140	140	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	140	130	5	2 A	5	−1A					50*	190	15	162	2SA1227とコンプリ ○
〃 2988	松下	〃	Si. EP	36	16	500	5 W (Tc=25°C)	150	10	20	50	13.5	200	10	−100	P_o=2.2W, η=60% (V_{CC}=13.5V, f=175MHz, P_i=0.2W)				1000*	6	26*	222	
〃 2989	〃	〃	〃	36	18	1 A	15W (Tc=25°C)	150	100	20	80	13.5	400	10	−300	P_o=10.5W (V_{CC}=13.5V, f=175MHz, P_i=2 W)				600*	25	9.5*	268C	
★ 〃 2990	〃																							
〃 2991	〃	PA	Si. EP	36	16	600	10W (Tc=25°C)	150	10	20	50	13.5	200	10	−100	P_o=2.2W (V_{CC}=13.5V, f=470MHz, P_i=0.2W)				2000*	5.5	18*	353	
〃 2992	〃	〃	〃	36	16	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	100	20	50	13.5	400	10	−200	P_o=11W, η 60% (V_{CC}=13.5V, f=470MHz, P_i=2 W)				2000*	25	17*	353	
★ 〃 2993																								
★ 〃 2994																								
〃 2995	東芝	RF	Si. E	40	30	50	200	125	0.1	40	140	6	1	6	−1					350*	1.6	15	287	
〃 2996	〃	〃	〃	40	30	50	150	125	0.1	40	140	6	1	6	−1					350*	1.6	15	176	
〃 2997	日電	〃	〃	20	10	80	350	200	1	8	100	8	20	8	−20	G_{max}=15.5dB, NF=1.5dB (1GHz) (8V, 5mA, 1GHz)				8000*	0.4		320	
〃 2998	三洋	SW	Si. EP	60	50	150	400	150	0.1	40	240	6	1			t_r<130ns, t_f<220ns t_{stg}<450ns							138	
〃 2999	〃	RF	〃	25	20	30	150	125	0.1	10	100	6	1	6	−4					750*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 15ps	92	
〃 3000	〃	〃	〃	30	20	30	250	125	0.1	10	200	6	1	6	−1					320*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 15ps	138	
〃 3001	三菱	PA	〃	20	9	3 A	20W (Tc=25°C)	175	500	10	50	5	100			P_o= 7 W (V_{CC}=7.2V, f=175MHz, P_i=0.3W)							272A	
★ 〃 3002																								
★ 〃 3003																								
〃 3004	日立	SW	Si. E	30	30	3 A	10W (Tc=25°C)	150	20	24	10000	3	1.5A			t_{on}<1 μs, t_{off}<2 μs t_{stg}<1.5μs							160	ダーリントン
〃 3005	〃	Osc	〃	15	10	50	150	125	0.3	12	200	4	5	4	−5	V_{osc}=35mV (6 V, 5 mA, 930MHz)				1600*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176	
〃 3006	東芝	PA	〃	35	17	1 A	10W (Tc=25°C)	175	1 mA	15	50	5	500			P_o= 4 W (V_{CC}=12.6V, f=470MHz, P_i=0.4W)							279	
〃 3007	〃	RF. AF	〃	50	50	2 A	8 W (Tc=25°C)	175	1	50	130	2	500	2	−500					100*	30	7*	84B	
〃 3008	日電	PA	〃	35	18	10A	70W (Tc=25°C)	200	2 mA	20	60	10	1 A			P_o=40W (V_{CC}=13.5V, f=175MHz, P_i=7.9W)					60		326	
〃 3009	〃	〃	〃	25	12	1.5A	17.5W (Tc=25°C)	200	200	20	60	7	200			P_o=3.5W (V_{CC}=7.2V, f=860MHz, P_i= 1 W)					8		326	
〃 3010	〃	〃	〃	25	12	3 A	35W (Tc=25°C)	200	400	20	60	7	400			P_o=5.5W (V_{CC}=7.2V, f=860MHz, P_i=2.5W)					16*		326	
〃 3011	東芝	RF	〃	20	7	30	150	125	1	10	120	5	10	5	−10	NF= 4 dB (5 V, 5 mA, 2 GHz)				6500*	0.7	66*	176	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SC3012	日電	PA	Si. T	130	130	10A	100W (Tc=25°C)	150	50	120	130	5	2 A	5	−1A					60 *	150	15	162	
★	〃 3013	日立	Osc	Si. E	15	10	50	150	125	0.5	12	80	4	5	4	−5	V_{osc}=200mV (6V, 5mA, 300MHz)				900 *	0.9	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176	
★	〃 3014	〃	Conv	〃	15	10	50	150	125	0.5	12	90	4	5	4	−5	G_{ce}=14.9dB (6V, 2mA, 900MHz)				3000*	98	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	176	
★	〃 3015	〃	〃	〃	15	10	50	150	150	0.5	12	100	4	5	4	−5	G_{ce}=21dB (6V, 2mA, 200MHz)				1300*	1	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176	
	〃 3016	〃	Osc	〃	15	10	50	150	150	0.5	8	90	4	5	4	−5	V_{osc}=120mV (6V, 5mA, 930MHz)				1450*	0.95	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176	
	〃 3017	三菱	PA	Si. EP	20	9	600	4 W (Tc=7°C)	175	200	10	50	5	100			P_o=1.7W (V_{CC}=7.2V, f=175MHz, P_i=0.1W)							84B	エミッタケース接続
	〃 3018	〃	〃	〃	20	9	1.5A	10W (Tc=25°C)	175	300	10	50	5	100			P_o=3.5W (V_{CC}=7.2V, f=175MHz, P_i=0.15W)							272A	
	〃 3019	〃	〃	〃	35	17	400	900 (Tc=25°C)	135	500	15	70	10	50			P_o=600mW (V_{CC}=12.5V, f=520MHz, P_i=20mW)							354	
	〃 3020	〃	〃	〃	35	17	1 A	10W (Tc=25°C)	175	300	15	50	10	100			P_o=3.3W (V_{CC}=12.5V, f=520MHz, P_i=0.3W)							272A	
	〃 3021	〃	〃	〃	35	17	2 A	20W (Tc=25°C)	175	500	15	50	10	100			P_o= 8 W (V_{CC}=12.5V, f=520MHz, P_i=1.2W)							272A	
	〃 3022	〃	〃	〃	35	17	7 A	50W (Tc=25°C)	175	2 mA	15	50	10	1 A			P_o= 22W (V_{CC}=12.5V, f=520MHz, P_i= 6 W)							272A	
★	〃 3023	日立	SW	Si. T	1500	17	3 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1500	10	5	300			t_{on}< 2 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							102	
★	〃 3024	〃	〃	〃	1700	800	3 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1700	10	5	300			t_{on}< 2 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							102	
	〃 3025	〃	〃	〃	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1500	20	5	300			t_{on}<1.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							102	
	〃 3026	〃	〃	〃	1700	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1700	20	5	300			t_{on}<1.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							102	
★	〃 3027	〃	〃	〃	1500	800	8 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1500	15	5	300			t_{on}< 2 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							102	
★	〃 3028	〃	〃	〃	1700	800	8 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1700	15	5	300			t_{on}< 2 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							102	
	〃 3029	日電	RF	Si. E	15	8	5	50	150	0.1	5	120	1	0.25	1	−0.5	G_{max}=14dB, NF= 3 dB (1 GHz) (1V, 0.25mA, 1GHz)				4000*			210B	
	〃 3030	富士電機	SW	Si. TP	900	800	7 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	15	5	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.8μs t_{stg}<2.5μs							211	ダーリントン
	〃 3031	〃	〃	〃	900	800	7 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	15	5	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.8μs t_{stg}<2.5μs							102	ダーリントン
	〃 3032	〃	〃	〃	900	700	7 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	15	5	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.8μs t_{stg}<2.5μs							211	ダーリントン
	〃 3033	〃	〃	〃	900	700	7 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	15	5	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.8μs t_{stg}<2.5μs							102	ダーリントン
★	〃 3034	〃	〃	〃	250	200	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	250	40	5	2 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							102	
	〃 3035	オリジン	〃	Si. T	300	200	5 A	40W (Tc=25°C)	150	30	200	15	5	2 A			t_{on}<1.5μs, t_f< 1 μs t_{stg}<3.5μs							153	
	〃 3036	〃	〃	〃	800	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	3	640	15	5	2 A			t_{on}<1.5μs, t_f< 1 μs t_{stg}<3.5μs							153	
★	〃 3037	ソニー	RF	Si. E	20	15	70	400	150	0.2	19	80	10	10	10	−10	NF=1.2dB (10V, 3mA, 500MHz)				5000*	0.85	$C_c r_{bb'}$ 2.7ps	138C	
	〃 3038	三洋	SW	Si. EP	500	400	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	400	45	5	400			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							268	
	〃 3039	〃	〃	〃	500	400	7 A	50W (Tc=25°C)	150	10	400	40	5	800			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							268	
	〃 3040	〃	〃	〃	500	400	8 A	80W (Tc=25°C)	150	10	400	40	5	800			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							346	
★	〃 3041	〃	〃	〃	500	400	8 A	80W (Tc=25°C)	150	10	400	40	5	800			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							102	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3042	三洋	SW	Si.EP	500	400	12A	100W (Tc=25°C)	150	10	400	40	5	1.6A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							346	
★ 〃 3043	〃	〃	〃	500	400	12A	120W (Tc=25°C)	150	10	400	40	5	1.6A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							102	
〃 3044	富士通	〃	〃	450	400	6 A	100W (Tc=25°C)	175	100	450	15	5	3 A	10	−1A	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs				30 *	100		102	○
〃 3045	〃	〃	〃	450	400	10A	100W (Tc=25°C)	175	100	450	17	5	5 A	10	−1A	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.5μs				32 *	100		102	
〃 3046	〃	〃	〃	600	450	10A	100W (Tc=25°C)	175	100	500	14	5	6 A	10	−2A	t_r<0.3μs, t_f<0.2μs t_{stg}<1.5μs				28 *	230		102	
〃 3047	富士電機	〃	Si.TP	850	500	6 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	850	20	5	500			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							268	
〃 3048	〃	〃	〃	850	500	6 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	850	20	5	500			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							102	
〃 3049	〃	〃	〃	850	500	10A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	850	20	5	500			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							102	
〃 3050	富士通	〃	Si.T	1200	800	5 A	150W (Tc=25°C)	175	1 mA	1000	18	5	1.5A			t_r<0.5μs, t_f<1μs t_{stg}<3.5μs							102	
★ 〃 3051	東芝	〃	〃	500	400	800	10W (Tc=25°C)	150	100	400	55	5	100			t_r<1μs, t_f<1.5μs t_{stg}<2.5μs							342	
〃 3052	三菱	AF	Si.EP	50	50	200	150	125	0.1	50	300	6	1	6	−1	300	8.5k	1	5.5	200 *	2.5	C_c $r_{bb'}$ 100ps	176	2SA1235 とコンプリ
〃 3053	〃	RF	〃	30	25	30	150	125	1	25	80	6	1	6	−1	NF=3dB (f=10.7MHz)				200 *	2	C_c $r_{bb'}$ 20ps	176	
〃 3054	松下	SW	Si.TMe	500	500	20A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	500	350	5	20A			t_{on}<1μs, t_f<1.5μs t_{stg}<4μs							365	ダーリントンダンパ内蔵
〃 3055	富士通	〃	Si.EP	450	400	2 A	15W (Tc=25°C)	150	10	300	35	5	100	10	−200	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3μs				28 *	25		268	
〃 3056	〃	〃	〃	450	400	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	450	15	5	3 A	10	−1A	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs				30 *	100		268	○
〃 3057	〃	〃	〃	450	400	10A	50W (Tc=25°C)	150	100	450	16	5	5 A	10	−1A	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.5μs				32 *	100		268	
〃 3058	〃	〃	〃	600	400	30A	200W (Tc=25°C)	175	100	500	14	5	20A	10	−4A	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3μs				30 *	420		102	○
〃 3059	〃	〃	Si.TP	1200	850	2 A	100W (Tc=25°C)	175	100	1000	15	5	1 A	10	−200	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3.5μs				15 *	60		102	
〃 3060	〃	〃	〃	1200	850	5 A	150W (Tc=25°C)	175	100	1000	15	5	2 A	10	−500	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3.5μs				15 *	120		102	
〃 3061	〃	〃	〃	1200	850	10A	200W (Tc=25°C)	175	100	1000	15	5	4 A	10	−100	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3.5μs				15 *	220		102	
〃 3062	日電	RF	Si.E	25	12	65	400	200	0.1	8	100	8	7	8	−10	$\|S_{21e}\|^2$=12dB (2GHz) NF=1.6dB (2GHz)				8500 *			320	
★ 〃 3063	松下	〃	Si.TP	300	300	100	1.2W	150			50~250	50	5	30	−20					140 *	2.4		236	
〃 3064	三洋	Diff	Si.EP	55	50	150	250/unit	150	0.1	35	500	6	1	6	−1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.85~1.0 ΔV_{BE}<10mV				100 *	2.5	C_c $r_{bb'}$ 250ps	355	2素子複合
〃 3065	〃	〃	〃	55	50	150	250/unit	150	0.1	35	500	6	1	6	−1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.85~1.0 ΔV_{BE}<10mV				100 *	2.5	C_c $r_{bb'}$ 250ps	355	2素子複合
〃 3066	〃	〃	〃	130	120	50	250/unit	150	0.1	80	500	6	1	6	−1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.85~1.0 ΔV_{BE}<10mV				160 *	1.6	C_c $r_{bb'}$ 40ps	355	2素子複合
〃 3067	〃	〃	〃	130	120	50	250/unit	150	0.1	80	500	6	1	6	−1	h_{FE1}/h_{FE2}=0.85~1.0 ΔV_{BE}<10mV				160 *	1.6	C_c $r_{bb'}$ 40ps	355	2素子複合
〃 3068	〃	RF	〃	30	25	300	600	150	0.1	20	1500	5	10	10	−10					250 *	4.5	C_c $r_{bb'}$ 170ps	138	
〃 3069	〃	〃	〃	60	50	200	600	150	0.1	40	1500	5	10	10	−10					250 *	4	C_c $r_{bb'}$ 130ps	138	
〃 3070	〃	〃	〃	30	25	1.2A	1 W	150	0.1	20	1500	5	500	10	−50					220 *	17	C_c $r_{bb'}$ 130ps	294	
〃 3071	〃	〃	〃	120	100	200	1 W	150	0.1	80	1500	5	10	10	−10					150 *	6.5	C_c $r_{bb'}$ 60ps	294	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3072	東芝	RF. AF. PA	Si. E	50	20	5 A	20W (Tc=25°C)	150	0.1	40	300	2	500	2	−500					100*	40	16	344	
〃 3073	〃	RF	〃	30	30	3 A	20W (Tc=25°C)	150	1	20	150	2	500	2	−500					100*	35	10	344	2SA1243 とコンプリ
〃 3074	〃	AF. PA. SW	〃	60	50	5 A	20W (Tc=25°C)	150	1	50	130	1	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<5μs							344	2SA1244 とコンプリ
〃 3075	〃	SW	Si. T	500	400	800	10W (Tc=25°C)	150	100	400	55	5	100			t_r<1μs, t_f<1.5μs t_{stg}<2.5μs							344	
〃 3076	〃	〃	Si. E	50	50	2 A	1 W	150	1	50	120	2	500	2	−500					100*	30	20	344	2SA1241 とコンプリ
〃 3077	松下	RF	Si. EP	30	20	20	150	125	1	25	40~200	10	3							1100*	0.7	10	176	
〃 3078	ローム	RF. AF	〃	40	32	100	250	125	0.5	24	82	6	2	12	−2					230*	1.8	$C_c r_{bb'}$ 10ps	360	
〃 3079	〃	RF	〃	25	20	20	150	125	0.5	20	82	6	1	6	−1					500*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 16ps	360	
〃 3080	〃	〃	〃	30	19	50	300	125	0.5	20	120	10	5	5	−10					1100*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	360	
〃 3081	〃	〃	〃	30	19	50	300	125	0.5	20	120	10	5	5	−10					1100*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138C	
〃 3082	〃	〃	〃	30	19	50	200	125	0.5	20	120	10	5	5	−10					1100*	1	$C_c r_{bb'}$ 10ps	335	
〃 3083	三洋	SW	Si. TP	500	400	6 A	60W (Tc=25°C)	150	10	400	40	5	400			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							346	
★ 〃 3084	〃	〃	〃	500	400	6 A	70W (Tc=25°C)	150	10	400	40	5	400			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							102	
〃 3085	〃	〃	〃	500	400	25A	140W (Tc=25°C)	150	10	400	40	5	3.2A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							102	
〃 3086	〃	〃	〃	800	500	3 A	40W (Tc=25°C)	150	10	500	30	5	300			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							268	
〃 3087	〃	〃	〃	800	500	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	30	5	600			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							268	
〃 3088	〃	〃	〃	800	500	4 A	60W (Tc=25°C)	150	10	500	30	5	300			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							346	
〃 3089	〃	〃	〃	800	500	7 A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	30	5	600			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							346	
〃 3090	〃	〃	〃	800	500	10A	100W (Tc=25°C)	150	10	500	30	5	1.2A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							346	
★ 〃 3091	〃	〃	〃	800	500	4 A	70W (Tc=25°C)	150	10	500	30	5	300			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							102	
★ 〃 3092	〃	〃	〃	800	500	7 A	90W (Tc=25°C)	150	10	500	30	5	600			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							102	
★ 〃 3093	〃	〃	〃	800	500	10A	120W (Tc=25°C)	150	10	500	30	5	1.2A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							102	
★ 〃 3094	〃	〃	〃	800	500	20A	160W (Tc=25°C)	150	10	400	40	5	2.4A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							102	
〃 3095	日電	PA	Si. E	25	16	110	2.75W (Tc=25°C)	200	0.25	15	20~200	8	50	8	−50	P_{osc}=21.5dBm (12V, 120mA, 7.5GHz)				6500*	0.65		366	NE243188
〃 3096	〃	〃	〃	25	16	220	5.5W (Tc=25°C)	200	0.5	15	20~200	8	100	8	−100	P_{osc}=25dBm (12V, 120mA, 7.5GHz)				6000*	1		366	NE243288
★ 〃 3097	〃																							
〃 3098	東芝	RF	Si. E	30	20	50	150	125	1	10	80	10	10	10	−10	NF=2.5dB (10V, 5mA, 500MHz)				3500*	1.15	60*	176	
〃 3099	〃	〃	〃	20	20	30	150	125	0.1	10	80	10	5	10	−10	NF=1.7dB (10V, 3mA, 500MHz)				4000*	0.9	50*	176	
★ 〃 3100	〃																							
〃 3101	三菱	PA	Si. EP	35	17	1 A	10W (Tc=25°C)	175	300	15	50	10	100			P_o=3.5W (V_{CC}=12.5V, f=520MHz, P_i=0.8W)							84B	エミッタケース接続

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3102	三菱	PA	Si.EP	35	17	18A	170W (Tc=25°C)	175	5 mA	15	50	10	2 A			P_o=65W (V_{CC}=12.5V, f=520MHz, P_i=20W)							303	
〃 3103	〃	〃	〃	20	9	1.5A	10W (Tc=25°C)	175	300	10	50	5	100			P_o=3.2W (V_{CC}=7.2V, f=520MHz, P_i=0.6W)							272A	
〃 3104	〃	〃	〃	20	9	3 A	20W (Tc=25°C)	175	500	10	50	5	100			P_o=7 W (V_{CC}=7.2V, f=520MHz, P_i=2 W)							272A	
〃 3105	〃	〃	〃	35	35R	10A	80W (Tc=25°C)	175	5 mA	15	50	10	1 A			P_o=35W (V_{CC}=12.5V, f=850MHz, P_i=15W)							24	
〃 3106	松下	〃	〃	36	16	600	10W (Tc=25°C)	175	100	20	80	10	200	10	−200	P_o=2 W (V_{CC}=12.5V, f=940MHz, P_i=0.06W)				2500*	3	5 *	345A	
〃 3107	〃	〃	〃	36	16	2 A	20W (Tc=25°C)	175	500	20	90	10	500	10	−500	P_o=5 W (V_{CC}=12.5V, f=940MHz, P_i=0.5W)				2000*	20	5 *	345A	
〃 3108	〃	〃	〃	36	16	2 A	30W (Tc=25°C)	175	1 mA	20	50	10	1 A	10	−200	P_o=14.5W (V_{CC}=12.5V, f=940MHz, P_i=2W)				2000*	35	5 *	345A	
〃 3109	〃	〃	〃	36	16	300	5 W (Tc=25°C)	175	100	20	80	10	100	10	−100	P_o=600mW (V_{CC}=10V, f=940MHz, P_i=30mW)				2500*	4	4.5 *	362	
〃 3110	〃	RF	〃	15	12	30	200	125	10	15	100	10	20	10	−10					4500*	<1.2	25 *	176	
〃 3111	〃	〃	〃	36	16	100	2 W (Tc=25°C)	175	100	36	80	10	50	10	−50					2500*	1.2	4 *	362	
〃 3112	東芝	AF.RF.SW	Si.E	50	50	150	400	125	0.1	50	1500	6	2	10	−10	t_{on}<150ns, t_f<200ns t_{stg}<900ns				250 *	3.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138	
〃 3113	〃	〃	〃	50	50	150	200	125	0.1	50	1500	6	2	10	−10	t_{on}<15ns, t_f<200ns t_{stg}<900ns				250 *	3.5	$C_c r_{bb'}$ 150ps	287	
〃 3114	三洋	RF.AF	Si.EP	60	50	150	400	150	0.1	40	250	6	1	6	−1					100 *	3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138	2SA1246とコンプリ
〃 3115	日電	RF.AF.LN	Si.E	120	120	50	200	150	0.1	120	500	6	1	6	−1	11k	10		40	110 *	1.6	50	176	
〃 3116	三洋	RF.AF	Si.EP	180	160	700	10W (Tc=25°C)	150	0.1	120	250	5	100	10	−50					120 *	8	$C_c r_{bb'}$ 25ps	296	2SA1248とコンプリ
〃 3117	〃	〃	〃	180	160	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	1	120	250	5	100	10	−50	t_{on}=0.04μs, t_f=0.08μs t_{stg}=1.2μs				120 *	14	$C_c r_{bb'}$ 30ps	296	
★ 〃 3118	富士通	SW	〃	400	360	150	350	150	10	40	70	10	20			t_{on}<300ns, t_f<300ns t_{stg}<2 μs							49C	
〃 3119	東芝	RF	Si.P	25	20	20	150	125	0.1	10	100	10	2	10	−2					900 *	0.85	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	176	フォワードAGC
〃 3120	〃	〃	Si.E	30	15	50	150	125	0.1	15	100	10	5	10	−2					2400*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	176	フォワードAGC
〃 3121	〃	〃	Si.EP	30	15	50	150	125	0.1	15	150	3	8	10	−8					1500*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 7 ps	176	
〃 3122	〃	〃	Si.P	30	30	20	150	125	0.1	25	150	10	2	10	−2					650 *	1	$C_c r_{bb'}$ 11.5ps	176	フォワードAGC
〃 3123	〃	〃	Si.E	30	20	50	150	125	1	25	150	10	2	10	−2					1400*	0.4	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176	
〃 3124	〃	〃	〃	30	15	50	150	125	0.1	15	100	3	8	10	−8					1100*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 7 ps	176	
〃 3125	〃	〃	〃	30	25	50	150	125	0.1	30	70	10	10	12.5	−12.5					600 *	1.1	$C_c r_{bb'}$ 15ps	176	
〃 3126	日立	RF.AF	〃	20	12	50	200	150	0.5	12	90	5	20	5	−20	G_{pe}=10.5dB (f=900MHz)				4500*	0.9	51 *	240C	
〃 3127	〃	〃	〃	20	12	50	150	150	0.5	12	90	5	20	5	−20	G_{pe}=10.5dB (f=900MHz)				4500*	0.9	52 *	176	
〃 3128	〃	〃	〃	20	12	50	350	150	0.5	12	90	5	20	5	−20	G_{pe}=10.5dB (f=900MHz)				4500*	0.9	53 *	138C	
〃 3129	〃		Si.T	500	400	500	10W (Tc=25°C)	150	20	400	18	5	250			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2 μs							245	
〃 3130	松下	RF.AF	Si.EP	15	10	50	150	125	1	10	200	4	5	4	−5					1900*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 11ps	176	
〃 3131	富士電機	SW	Si.TP	600	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	600	30	5	5 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 4 μs							102	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3132	日立	SW	Si. E	30	30	3 A	10W (Tc=25°C)	150	20	24	10000	3	1.5A			t_{on}< 1 μs, t_{off}< 2 μs t_{stg}<1.5μs							245	ダーリントン
〃 3133	三菱	PA	Si. EP	60	25	6 A	20W (Tc=25°C)	150	500	30	50	12	10			P_o=16W (V_{CC}=12V, f=27MHz, P_i=0.5W)							301A	
〃 3134	三洋	AF	〃	60	50	150	200	125	0.1	40	100~560	6	1	6	−1	P_o=11W (V_{CC}=13.5V, f=470MHz, P_i= 2 W)				100*	2.2		176	2SA1252 とコンプリ
〃 3135	〃	RF. AF	〃	60	50	200	250	150	0.1	40	250	6	1	6	−1					100*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	92	2SA1253 とコンプリ
〃 3136	東芝	RF	Si. E	30	20	50	250	125	1	25	150	10	2	10	−2					1100*	0.4	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138C	
〃 3137	〃	〃	Si. EP	30	15	50	200	125	0.1	15	100	10	5	10	−5					2000*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	347A	
〃 3138	〃	〃	Si. T	200	200	50	150	125	0.1	200	120	3	10	10	−2					100*	2	30	176	2SA1255 とコンプリ
〃 3139	日電	PA	Si. E	50	30	1 A	12W (Tc=25°C)	200	100	30	60	10	150			P_o=1.2W (V_{CC}=24V, f=860MHz, P_i=100mW)					2		129	
〃 3140	〃	〃	〃	50	30	2 A	17.5W (Tc=25°C)	200	200	30	60	10	300			P_o=2.4W (V_{CC}=24V, f=860MHz, P_i=250mW)					4		129	
〃 3141	〃	〃	〃	50	30	4 A	32W (Tc=25°C)	200	400	30	60	10	600			P_o= 5 W (V_{CC}=24V, f=860MHz, P_i=400mW)							43	
〃 3142	三洋	RF. Conv Mix. Osc	Si. EP	25	20	30	150	125	0.1	10	80	6	1	6	−4	G_{pc}=28dB (6 V, 1 mA, 100MHz)				750*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 15ps	176	
〃 3143	〃	RF. AF	〃	180	160	80	200	125	0.1	120	150	5	10	10	−10	t_{on}=0.18μs, t_f=0.2μs t_{stg}= 1 μs				150*	2	$C_c r_{bb'}$ 15ps	176	
〃 3144	〃	AF. PA	〃	70	60	3 A	20W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	1.5A	5	−1.5A	t_{on}=0.3μs, t_f=0.2μs t_{stg}=1.2μs				200*			268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 3145	〃	〃	〃	70	60	5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	2.5A	5	−2.5A					200*			268	ダーリントン ダンパ内蔵
★ 〃 3146	〃	〃	〃	70	60	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	3.5A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 3147	東芝	PA	Si. E	36	16	14A	150W (Tc=25°C)	175	5 mA	15	70	5	5 A			P_o=60W (V_{CC}=12.5V, f=175MHz, P_i=10W)							371	
〃 3148	〃	SW	Si. T	900	800	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	800	15	5	800			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<3.5μs							268	
〃 3149	三洋	〃	Si. TP	900	800	1.5A	40W (Tc=25°C)	150	10	800	>10	5	100	10	−100	t_{on}= 1 μs, t_f=0.7μs t_{stg}=2.5μs				15*	30		268	
〃 3150	〃	〃	〃	900	800	3 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	>10	5	200	10	−200	t_{on}= 1 μs, t_f=0.7μs t_{stg}=2.5μs				15*	60		268	
〃 3151	〃	〃	〃	900	800	1.5A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	>10	5	100	10	−100	t_{on}= 1 μs, t_f=0.7μs t_{stg}=2.5μs				15*	30		346	
〃 3152	〃	〃	〃	900	800	3 A	80W (Tc=25°C)	150	10	800	>10	5	200	10	−200	t_{on}= 1 μs, t_f=0.7μs t_{stg}=2.5μs				15*	60		346	
〃 3153	〃	〃	〃	900	800	6 A	100W (Tc=25°C)	150	10	800	>10	5	400	10	−400	t_{on}= 1 μs, t_f=0.7μs t_{stg}=2.5μs				15*	120		346	
★ 〃 3154	〃	〃	〃	900	800	1.5A	70W (Tc=25°C)	150	10	800	>10	5	100	10	−100	t_{on}= 1 μs, t_f=0.7μs t_{stg}=2.5μs				15*	30		102	
〃 3155	〃	〃	〃	900	800	3 A	90W (Tc=25°C)	150	10	800	>10	5	200	10	−200	t_{on}= 1 μs, t_f=0.7μs t_{stg}=2.5μs				15*	60		102	
〃 3156	〃	〃	〃	900	800	6 A	120W (Tc=25°C)	150	10	800	>10	5	400	10	−400	t_{on}= 1 μs, t_f=0.7μs t_{stg}=2.5μs				15*	120		102	
〃 3157	日電	〃	Si. E	150	100	10A	60W (Tc=25°C)	150	10	100	40~200	5	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							370	2SA1261 とコンプリ
〃 3158	〃	〃	Si. T	500	400	7 A	60W (Tc=25°C)	150	10	400	40	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							370	
〃 3159	〃	〃	〃	500	400	10A	80W (Tc=25°C)	150	10	400	35	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							370	
〃 3160	〃	〃	Si. E	200	100	7.5A	40W (Tc=25°C)	150	10	150	35	5	5 A			t_{on}< 2 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							370	ダンパ内蔵
★ 〃 3161	富士通	RF	Si. EP	25	12	70	150	125	0.1	10	100	10	10	10	−10	NF= 2 dB (10V, 5 mA, 1 GHz)				5000*	1.4	40*	176	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備備考
2SC3162	新電元	SW	Si.TP	500	400	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	500	15	2	1.5A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}< 1 μs				20 *			268	T3V40F3
〃 3163	〃	〃	〃	500	400	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	500	15	2	3 A	10	−600	t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}< 1 μs				20 *			268	T6V40F3
〃 3164	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	15	2	5 A	10	−1A	t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}< 1 μs				20 *			119	T10W40F3
〃 3165	〃	〃	〃	500	400	3 A	60W (Tc=25°C)	150	100	500	15	2	1.5A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}< 1 μs				20 *			204	T3M40F3
〃 3166	〃	〃	〃	500	400	6 A	80W (Tc=25°C)	150	100	500	15	2	3 A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}< 1 μs				20 *			204	T6M40F3
〃 3167	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	15	2	5 A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}< 1 μs				20 *			102	T10M40F3
〃 3168	〃	〃	〃	500	400	20A	200W (Tc=25°C)	150	100	500	15	2	10A	10	−2A	t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}< 1 μs				20 *			103	T20M40F3
〃 3169	松下	〃	〃	500	400	2 A	25W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	1 A	10	−200	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs				> 8 *			364	
〃 3170	〃	〃	〃	500	400	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	3 A	10	−200	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs				> 8 *			364	
〃 3171	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	5 A	10	−200	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs				> 8 *			365	
〃 3172	東芝	RF	Si.EP	30	20	50	200	125	0.1	25	150	10	5	10	− 5					1400*	1	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	347C	
〃 3173	三洋	SW	〃	330	150	7 A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	50	1	1 A	10	−500	t_f<0.7μs				40 *			268	水平偏向用
〃 3174	〃	〃	〃	330	150	7 A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	50	1	1 A	10	−500	t_f<0.7μs				40 *			268	水平偏向用 ダンパ内蔵
〃 3175	〃	〃	〃	400	200	7 A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	50	1	1 A	10	−500	t_f<0.7μs				40 *			268	水平偏向用 ダンパ内蔵
〃 3176	〃	〃	〃	400	200	7 A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	50	1	1 A	10	−500	t_f<0.7μs				40 *			268	水平偏向用 ダンパ内蔵
〃 3177	松下	RF	〃	15	10	50	250	125	1	10	200	4	5	4	− 5					1900*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 11ps	138	
〃 3178	富士通	SW	Si.TP	1200	850	2 A	60W (Tc=25°C)	150	100	1000	15	5	1 A	10	−200	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3.5μs				15 *	60		268	
〃 3179	サンケン	PA.SW	〃	60		4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	100	4	1 A	12	−200	t_{on}=0.2μs, t_f=0.29μs t_{stg}=1.9μs				15 *			298	2SA1262 とコンプリ
〃 3180	東芝	PA	Si.T	80	80	6 A	60W (Tc=25°C)	150	5	80	95	5	1 A	5	−1A					30 *	105	20	203	2SA1263 とコンプリ
〃 3181	〃	〃	〃	120	120	8 A	80W (Tc=25°C)	150	5	120	95	5	1 A	5	−1A					30 *	190	15	203	2SA1264 とコンプリ
〃 3182	〃	〃	〃	140	140	10A	100W (Tc=25°C)	150	5	140	95	5	1 A	5	−1A					30 *	220	10	203	2SA1265 とコンプリ
〃 3183	三洋	SW	Si.TP	900	800	200	25W (Tc=25°C)	150	10	800	20	5	100	10	−20	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs				15 *	10		268	
〃 3184	〃	〃	〃	900	800	500	30W (Tc=25°C)	150	10	800	20	5	300	10	−60	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs				15 *	20		268	
〃 3185	日電	PA	Si.E	35	18	400	7 W (Tc=25°C)	200	100	20	60	10	100			P_o=1.4W (V_{CC}=12.6V, f=500MHz, P_i=0.25W)							84B	
〃 3186	サンケン	〃	Si.TP	200	200	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	200	2000	4	1 A	12	−200					60 *	40	180	298	ダーリントン
〃 3187	松下	RF	Si.EP	300	300	100	750	150	1	100	150	50	5	30	−20					140 *	1.9	40	138	
〃 3188																								
〃 3189	三洋	SW	Si.EP	250	100	7.5A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	25	5	5 A	10	−500	t_f< 1 μs				40 *			268	水平偏向用
〃 3190	韓国電子	RF	〃	35	30	100	400	125	0.1	20	85	12	2	10	− 2	NF= 2 dB (10V, 1 mA, 1 MHz)				120 *	3	$C_c r_{bb'}$ 30ps	138	
〃 3191	〃	〃	〃	35	30	100	200	125	0.1	35	85	12	2	10	− 2	NF= 2 dB (10V, 1 mA, 1 MHz)				120 *	3	$C_c r_{bb'}$ 30ps	287	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3192	韓国電子	RF. Conv. Osc	Si.EP	35	30	50	300	125	0.1	35	110	12	2	10	−1	G_{pe}=29dB (6V, 1mA, 10.7MHz)				175*	2	$C_{r\,rbb'}$ 29ps	138	
〃 3193	〃	〃	〃	35	30	50	200	125	0.1	35	110	12	2	10	−1	G_{pe}=30dB (6V, 1mA, 1MHz)				175*	2	$C_{r\,rbb'}$ 29ps	287	
〃 3194	〃	RF.Mix	〃	40	30	20	100	125	0.5	18	70	6	1	6	−1	G_{pe}=20dB (100MHz) NF=2.5dB (100MHz)				550*	1	$C_{r\,rbb'}$ 10ps	138	
〃 3195	〃	〃	〃	40	30	20	100	125	0.5	40	70	6	1	6	−1	G_{pe}=18dB (100MHz) NF=2.5dB (100MHz)				550*	1	$C_{r\,rbb'}$ 10ps	287	
〃 3196	〃	〃	Si.P	40	40	50	250	125	0.1	40	120	10	4	10	−4	G_{pe}=35dB (45MHz) I_{AGC}=7.2〜10.8mA				530*	0.95	$C_{r\,rbb'}$ 12ps	138	フォワードAGC
〃 3197	〃	RF	Si.EP	30	25	50	300	125	0.1	30	70	12.5	12.5	12.5	−12.5	G_{pe}=28〜36dB (45MHz)				660*	1.4	$C_{r\,rbb'}$ 11ps	138	
〃 3198	〃	RF.AF	〃	60	50	150	400	125	0.1	60	240	6	2	10	−1	NF= 1dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				130*	2	50	138	2SA1266とコンプリ
〃 3199	〃	〃	〃	50	50	150	200	125	0.1	50	240	6	2	10	−1	NF= 1dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				130*	2	50	287	2SA1267とコンプリ
〃 3200	〃	RF.AF.LN	〃	120	120	100	300	125	0.1	120	400	6	2	10	−1	NF< 6dB (6V, 0.1mA, 10Hz)				100*	3	13	138	2SA1268とコンプリ
〃 3201	〃	RF.AF	〃	120	120	100	200	125	0.1	120	400	6	2	10	−1	NF= 1dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				100*	3	13	287	2SA1269とコンプリ
〃 3202	〃	〃	〃	35	30	500	500	150	0.1	35	150	1	100	6	−20					300*	7	$C_{r\,rbb'}$ 40ps	138	2SA1270とコンプリ
〃 3203	〃	〃	〃	35	30	800	600	150	0.1	35	210	1	100	5	−10					120*	13	5	138	2SA1271とコンプリ
〃 3204	〃	〃	〃	35	30	800	300	150	0.1	30	210	1	100	5	−10					120*	13	5	287	2SA1272とコンプリ
〃 3205	〃	RF.AF.PA	〃	30	30	2A	1W	150	0.1	30	195	2	500	2	−500					120*	30	4	241	2SA1273とコンプリ
〃 3206	〃	RF.AF	Si.T	200	150	50	800	150	0.1	200	110	5	10	30	−10					120*	3.5	8	241	
〃 3207	〃	〃	〃	300	300	100	900	150	1	240	90	10	20	10	−20					70*	3	7	241	
〃 3208	〃	RF.AF PA.SW	〃	300	300	150	1.5W	150	1	100	100	10	50	10	−30	t_{on}<0.77μs, t_f<1.4μs t_{stg}<10μs				100*	5	7	268	
〃 3209	日電	RF.AF.PA	〃	300	300	200	1W	150	0.1	200	150	10	10	30	−10					50*	2.8	$C_{r\,rbb'}$ 300ps	278	
〃 3210	松下	SW	Si.TMe	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	5A	10	−500	t_{on}< 1μs, t_f< 1μs t_{stg}<2.5μs				>11*			82	
〃 3211	〃	〃	〃	800	500	5A	70W (Tc=25°C)	150	100	800	13	5	3A	10	−500	t_{on}< 1μs, t_f< 1μs t_{stg}< 3μs				> 3*			82	○
〃 3212	〃	〃	〃	800	500	7A	100W (Tc=25°C)	150	100	800	13	5	5A	10	−500	t_{on}< 1μs, t_f< 1μs t_{stg}<2.5μs				>3.5*			82	○
〃 3213	オリジン	〃	〃	800	400	75A	300W (Tc=25°C)	150	50	640	15	5	30A			t_{on}<1.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 4μs							121	
〃 3214	〃	〃	〃	1200	800	5A	80W (Tc=25°C)	150	50	960	15	5	1.5A			t_{on}< 1μs, t_f< 0.5μs t_{stg}< 4μs							102	
〃 3215	〃	〃	〃	1200	800	10A	125W (Tc=25°C)	150	50	960	15	5	3A			t_{on}< 1μs, t_f< 1μs t_{stg}< 4μs							102	
〃 3216	〃	〃	〃	1200	800	20A	200W (Tc=25°C)	150	50	960	15	5	6A			t_{on}< 1μs, t_f< 1μs t_{stg}< 4μs							102	
〃 3217	日電	PA	Si.E	50	32	12A	100W (Tc=25°C)	200	2mA	30	60	10	800			P_o=16W (V_{CC}=24V, f=860MHz, P_i=2W)					Cre 24		372	2素子複合(プッシュプル)
〃 3218	〃	〃	〃	55	32	15A	160W (Tc=25°C)	200	4mA	30	60	10	1A			P_o=52W (V_{CC}=28V, f=860MHz, P_i=10W)					Cre 40		372	2素子複合(プッシュプル)
〃 3219	新電元	PA.SW	Si.T	230	230	6A	50W (Tc=25°C)	150	100	230	15	2	6A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}<0.5μs				20*			268	T6V20F3
〃 3220	〃	〃	〃	230	230	10A	80W (Tc=25°C)	150	100	230	15	2	10A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}<0.5μs				20*			119	T10W20F3
〃 3221	〃	〃	〃	230	230	6A	80W (Tc=25°C)	150	100	230	15	2	6A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}<0.5μs				20*			204	T6M20F3

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ / f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3222	新電元	PA. SW	Si. T	230	230	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	230	15	2	10A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}<0.5μs				20 *			102	T10M20F3
〃 3223	〃	〃	〃	230	230	20A	200W (Tc=25°C)	150	100	230	15	2	20A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}<0.5μs				20 *			103	T20M20F3
〃 3224	〃	〃	〃	230	230	30A	300W (Tc=25°C)	150	100	230	15	2	30A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.1μs t_{stg}<0.5μs							266	T30M20F3
〃 3225	東芝	RF. SW	Si. E	40	40	2 A	900	150	10	40	1000	1	400	2	−100	t_{on}< 3 μs, t_f<3.5μs t_{stg}<10μs				220 *	20	10 *	241	
〃 3226	韓国電子	RF. AF	Si. EP	30	10	2 A	900	150	0.1	30	370	1	500	1	−500					150 *	27	4	241	
〃 3227	〃	〃	〃	80	80	400	800	150	0.1	50	120	2	50	10	−10					100 *	10	4	241	2SA1274 とコンプリ
〃 3228	〃	〃	〃	160	160	1 A	900	150	1	150	190	5	200	5	−200					100 *	12.8	5	241	2SA1275 とコンプリ
〃 3229	〃	RF. SW	Si. T	300	300	50	1.5W	150	1	240	115	10	20	20	−20					95 *	3.1	7	32	
〃 3230	〃	RF. PA	Si. EP	30	30	3 A	10W (Tc=25°C)	150	1	20	125	2	500	2	−500					100 *	35	6	268	
〃 3231	〃	RF.AF.PA	Si. T	200	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	170	30~150	5	1 A	5	−500	t_{on}< 3 μs, t_f<3.5μs t_{stg}< 6 μs				8 *	100	6	268	
★ 〃 3232	日電	SW	〃	900	400	6 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	30	10	2.5A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3.5μs							162	
〃 3233	東芝	〃	〃	500	400	2 A	10W (Tc=25°C)	150	100	400	30	5	100			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							344	
★ 〃 3234	〃	RF	〃	150	150	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	10	120	75	10	500	10	−500					4 *	35	25	51	
★ 〃 3235	〃	SW	〃	500	400	2 A	20W (Tc=25°C)	150	100	400	30	5	100			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							51	
★ 〃 3236	〃	〃	〃	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	400	20	5	3 A			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							51	
★ 〃 3237	〃	RF	Si. E	30	30	3 A	20W (Tc=25°C)	150	1	20	150	2	500	2	−500					100 *	35	10 *	51	
★ 〃 3238	〃	〃	〃	160	160	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	1	160	150	5	100	2	−100					100 *	25	15 *	51	
★ 〃 3239	〃	SW	〃	60	50	5 A	25W (Tc=25°C)	150	1	50	130	1	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							51	
〃 3240	三菱	PA	Si. EP	50	20	25A	270W (Tc=25°C)	175	5 mA	15	50	10	1 A			P_o=110W (V_{CC}=12.5V, f=30MHz, P_i= 7 W)							369	
〃 3241	〃	〃	〃	50	20	18A	180W (Tc=25°C)	175	5 mA	25	50	10	100			P_o=85W (V_{CC}=13.5V, f=30MHz, P_i= 4 W)							369	
〃 3242	〃	RF.AF.PA	〃	20	16	2 A	900	150	0.2	16	300	4	100	2	−10					80 *	28	$C_c r_{bb'}$ 250ps	6	2SA1282 とコンプリ ○
〃 3243	〃	〃	〃	60	60	1 A	900	150	0.2	50	200	4	100	2	−10					80 *	14	$C_c r_{bb'}$ 48ps	6	2SA1283 とコンプリ
〃 3244	〃	〃	〃	100	100	500	900	150	0.5	50	150	10	10	10	−10					130 *	6.5	$C_c r_{bb'}$ 20ps	6	2SA1284 とコンプリ
〃 3245	〃	〃	〃	120	120	100	900	150	0.1	100	450	10	10	10	−10					200 *	2.3	$C_c r_{bb'}$ 35ps	6	2SA1285 とコンプリ ○
〃 3246	〃	〃	〃	30	25	1.5A	900	150	0.1	20	1300	6	500	10	−10					130 *	17	$C_c r_{bb'}$ 440ps	6	2SA1286 とコンプリ
〃 3247	〃	〃	〃	50	50	500	900	150	0.1	40	1300	6	500	10	−10					130 *	17	$C_c r_{bb'}$ 440ps	6	2SA1287 とコンプリ
〃 3248	〃	〃	〃	180	180	100	900	150	0.5	100	150	10	10	10	−20					130 *	3.5	$C_c r_{bb'}$ 19ps	6	2SA1281 とコンプリ
〃 3249	〃	〃	〃	300	250	100	900	150	1	150	150	10	25	10	−10					80 *	3.5	$C_c r_{bb'}$ 25ps	6	
〃 3250	松下	RF	Si. TP	300	300	100	15W (Tc=25°C)	150	100	100	150	50	5	30	−20					100 *	3.7		268D	
〃 3251	〃	〃	Si. EP	55	30	400	15W (Tc=25°C)	150	100	10	50	5	50	15	−25					700 *	2.5		268C	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC3252	三洋	SW	Si.EP	80	60	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	60	170	2	1 A	5	−1A	t_{on}<0.1μs, t_f<0.2μs t_{stg}<1.4μs				100*			268	
〃 3253	〃	〃	〃	80	60	5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	170	2	1 A	5	−1A	t_{on}<0.1μs, t_f<0.2μs t_{stg}<1.4μs				100*			268	
〃 3254	〃	〃	〃	80	60	7 A	35W (Tc=25°C)	150	100	40	170	2	1 A	5	−1A	t_{on}<0.1μs, t_f<0.2μs t_{stg}<1.4μs				100*			268	
〃 3255	〃	〃	〃	80	60	10A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	170	2	1 A	5	−1A	t_{on}<0.1μs, t_f<0.2μs t_{stg}<1.4μs				100*			268	
〃 3256	〃	〃	〃	80	60	15A	70W (Tc=25°C)	150	100	60	170	2	1 A	5	−1A	t_{on}<0.1μs, t_f<0.2μs t_{stg}<1.4μs				100*			346	2SA1292とコンプリ
〃 3257	東芝	〃	Si.T	250	200	10A	40W (Tc=25°C)	150	100	200	30	5	5 A			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							268	
〃 3258	〃	〃	Si.E	100	80	5 A	25W (Tc=25°C)	150	1	80	150	1	.1 A			t_{on}<0.2μs, t_f<0.2μs t_{stg}<2μs							268	
〃 3259	新電元	〃	Si.TP	800	800	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	800	10	2	1.5A	10	−300	t_{on}<0.5μs, t_f<0.7μs t_{stg}<3μs				8*			268	ダーリントン
〃 3260	〃	〃	〃	800	800	3 A	50W (Tc=25°C)	150	100	800	10	2	1.5A	10	−300	t_{on}<0.5μs, t_f<0.7μs t_{stg}<3μs				8*			119	ダーリントン
〃 3261	〃	〃	〃	800	800	6 A	80W (Tc=25°C)	150	100	800	10	2	3 A	10	−600	t_{on}<0.5μs, t_f<0.7μs t_{stg}<3μs				8*			119	ダーリントン
〃 3262	〃	〃	〃	800	800	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	800	10	2	5 A	10	−1A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.7μs t_{stg}<3μs				8*			119	ダーリントン
〃 3263	サンケン	PA	〃	230	230	15A	130W (Tc=25°C)	150	100	230	70	4	5 A	12	−2A					60*	250	15	324	2SA1294とコンプリ
〃 3264	〃	〃	〃	230	230	17A	200W (Tc=25°C)	150	100	230	70	4	5 A	12	−2A					60*	250	15	324	2SA1295とコンプリ
〃 3265	東芝	RF	Si.EP	30	25	800	200	150	0.1	30	200	1	100	5	−10					120*	13	25	176	2SA1298とコンプリ
〃 3266	〃	〃	〃	30	30	2 A	750	150	0.1	30	350	2	100	2	−500					120*	30	8*	138	2SA1296とコンプリ
〃 3267	〃	〃	〃	30	30	2 A	400	150	0.1	30	300	2	100	2	−500					120*	30	8*	287	
〃 3268	〃	〃	Si.E	17	12	70	300	125	1	10	100	10	20	10	−20	NF=1.7dB (f=500MHz)				5000*	1.05	90*	336	
〃 3269	ローム	RF	Si.EP	300	300	100	750	150	0.5	200	82	10	10	30	−10					100*	6	$C_c r_{bb'}$ 100ps	294	
〃 3270	〃	〃	〃	300	300	100	750	135	0.5	200	82	10	10	30	−10					100*	6	$C_c r_{bb'}$ 100ps	235	
〃 3271	〃	〃	〃	300	300	100	5 W (Tc=25°C)	150	0.5	200	82	10	10	30	−10					100*	6	$C_c r_{bb'}$ 100ps	232	
〃 3272	〃	〃	〃	300	300	100	10W (Tc=25°C)	150	0.5	200	82	10	10	30	−10					100*	6	$C_c r_{bb'}$ 100ps	74	
〃 3273	松下	〃	〃	15	10	50	400	150	1	10	150	4	5	4	−5					2500*	0.85	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138	
〃 3274	〃	〃	〃	15	10	50	400	150	1	10	100	4	5	4	−5					1300*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138	
〃 3275	〃	〃	〃	15	10	50	400	150	1	10	100	4	5	4	−5					1800*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138	
〃 3276	〃	〃	〃	15	12	30	350	150	0.1	10	120	10	10	10	−10					7000*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 10ps	337A	
〃 3277	三洋	SW	Si.TP	500	400	10A	90W (Tc=25°C)	150	10	400	>15	5	1.2A	10	−1.2A	t_{on}=1μs, t_f=1μs t_{stg}=2.5μs				20*	120		346	
〃 3278	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	10	400	>15	5	1.2A	10	−1.2A	t_{on}=1μs, t_f=1μs t_{stg}=2.5μs				20*	120		102	
〃 3279	東芝	RF	Si.E	30	10	2 A	750	150	0.1	30	300	1	500	1	−500					150*	27	6	138	2SA1300とコンプリ
〃 3280	〃	PA	Si.T	160	160	12A	120W (Tc=25°C)	150	10	160	100	5	1 A	5	−1A					30*	250	10	152	2SA1301とコンプリ
〃 3281	〃	〃	〃	200	200	15A	150W (Tc=25°C)	150	10	200	100	5	1 A	5	−1A					30*	270	10	152	2SA1302とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SC3282	日電	PA	Si. E	35	16	7.5A	80W (Tc=25°C)	200	2 mA	20	50	10	1 A			P_o=23W, η=50% (f=860MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=4 W)				C_{re} 35			375A		○
★	〃 3283	〃	〃	〃	35	16	15A	146W (Tc=25°C)	200	4 mA	20	50	10	2 A			P_o=37W, η=48% (f=860MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=8 W)				C_{re} 70			375A		○
	〃 3284	サンケン	PA	Si. EP	150	150	14A	125W (Tc=25°C)	150	100	150	80	4	5 A	12	−2A					60*	200	15	324	2SA1303とコンプリ	
	〃 3285	松下	SW	Si.TMe	1000	800	4 A	80W (Tc=25°C)	150	100	1000	10	5	2 A			t_{on}<1.5μs, t_f<1 μs t_{stg}<3.5μs							365		
★	〃 3286	日電	PA	Si. E	55	32	24A	280W (Tc=25°C)	200	4mA	30	60	10	2 A			P_o=140W (f=230MHz, V_{CC}=28V, P_i=10W)					C_{re} 170		372		
	〃 3287	松下	〃	Si. EP	36	16	100	500	150	100	10	120	10	50	10	−50	P_o=80mW (f=915MHz, V_{CE}=8 V, P_i=5 mW)				2500*	2.5		337B		
	〃 3288	〃	〃	〃	36	16	300	2 W (Tc=25°C)	150	100	10	120	10	100	10	−100	P_o=350mW (f=915MHz, V_{CE}=8 V, P_i=50mW)				3000*	4		337B		
	〃 3289	〃	〃	〃	36	16	600	10W (Tc=25°C)	150	100	10	120	10	200	10	−200	P_o=1.5W (f=915MHz, V_{CE}=12.5V, P_i=0.2W)				2500*	4		345A		
	〃 3290	〃	〃	〃	36	16	2 A	20W (Tc=25°C)	150	100	10	120	10	500	10	−500	P_o=6.5W (f=915MHz, V_{CE}=12.5V, P_i=1.2W)				2500*	20		345B		
	〃 3291	〃	〃	〃	36	16	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	10	120	10	1 A	10	−1A	P_o=17W (f=915MHz, V_{CE}=12.5V, P_i=5 W)				2500*	45		345A		
	〃 3292	三洋	SW	〃	50	50	1.2A	20W (Tc=25°C)	150	10	40	4000	5	500	5	−500	t_{on}<0.2μs, t_f<0.4μs t_{stg}<2.2μs				180*			268	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 3293	〃	〃	〃	50	50	2 A	20W (Tc=25°C)	150	10	40	4000	5	1 A	5	−1A	t_{on}<0.2μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3.5μs				180*			268	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 3294	〃	〃	〃	50	50	3 A	20W (Tc=25°C)	150	10	40	4000	5	1.5A	5	−1.5A	t_{on}<0.2μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3.5μs				180*			268	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 3295	東芝	RF. SW	Si. E	50	50	150	150	125	0.1	50	1500	6	2	10	−10	t_{on}<0.15μs, t_f<0.2μs t_{stg}<0.9μs				250*	3.5		176		
	〃 3296	〃	RF	Si. T	150	150	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	10	120	75	10	500	10	−500					4*	35	25	381		
	〃 3297	〃	PA	Si. E	30	30	3 A	10W (Tc=25°C)	150	1	30	130	2	500	2	−500					100*	35	10	381	2SA1305とコンプリ	
	〃 3298	〃	〃	〃	160	160	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	160	130	5	100	10	−100					100*	25	4*	381	2SA1306とコンプリ	
	〃 3299	〃	SW	〃	60	50	5 A	20W (Tc=25°C)	150	1	50	120	1	1 A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3 μS							381		
	〃 3300	サンケン	〃	〃	150	50	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	600	0.5	500			t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<4 μs							324		
	〃 3301	東芝	RF	Si. E	15	7.5	80	300	125	0.1	10	100	3	50	5	−30		NF=2.3dB (5 V, 10mA, 1 GHz)			7000*	1.45	120*	336		
	〃 3302	〃	〃	〃	17	12	70	200	125	0.1	10	100	10	20	10	−20		NF=1.7dB (10V, 5 mA, 1 GHz)			5000*	0.8	70*	347C		
	〃 3303	〃	SW	〃	100	80	5 A	20W (Tc=25°C)	150	1	80	150	1	1 A	4	−1A	t_{on}<0.2μs, t_f<0.2μs t_{stg}<2 μs				120*	80		344		
★	〃 3304	〃	〃	Si. T	250	200	10A	40W (Tc=25°C)	150	100	250	30	5	5 A			t_r<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2.5μs							51		
★	〃 3305	〃	〃	〃	900	800	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	800	15	5	800			t_r<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<4 μs							51		
	〃 3306	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	20	5	5 A			t_r<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2.5μs							203		
	〃 3307	〃	〃	〃	900	800	10A	150W (Tc=25°C)	150	100	800	30	5	5 A			t_r<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2.5μs							152		
★	〃 3308	〃	〃	Si. E	100	80	5 A	30W (Tc=25°C)	150	1	80	150	1	1 A			t_r<0.2μs, t_f<0.2μs t_{stg}<2 μs							51	2SA1308とコンプリ	
	〃 3309	〃	〃	Si. T	500	400	2 A	20W (Tc=25°C)	150	100	400	30	5	100			t_r<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2.5μs							51		
	〃 3310	〃	〃	〃	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	400	20	5	3 A			t_r<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2.5μs							51		
	〃 3311	松下	RF. AF	Si. EP	30	25	100	300	125	0.1	20	250	10	2	10	−2					150*	3.5	30	376		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3312	松下	RF.AF.LN	Si.EP	55	55	50	300	125	0.1	10	400	5	2	5	−2	NF=1dB (10V, 1mA, 1kHz)				110*	3.5	30	376	2SA1310とコンプリ
〃 3313	〃	RF	〃	30	20	30	300	125	1	10	150	10	1	10	−1					230*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 13ps	376	
〃 3314	〃	〃	〃	30	20	30	300	125	1	10	150	10	1	10	−1					300*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 15ps	376	
〃 3315	〃	〃	〃	30	20	15	300	125	1	10	120	6	1	6	−1					650*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 12ps	376	
〃 3316	富士電機	SW	Si.TP	500	400	2A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	500	20	5	1A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.15μs t_{stg}<1.5μs							268	
〃 3317	〃	〃	〃	500	400	5A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	500	20	5	2A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.15μs t_{stg}<1.5μs							268	
〃 3318	〃	〃	〃	500	400	10A	80W (Tc=25°C)	150	1mA	500	15	5	5A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.15μs t_{stg}<1.5μs							211	
〃 3319	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	1mA	500	15	5	5A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.15μs t_{stg}<1.5μs							102	
〃 3320	〃	〃	〃	500	400	15A	80W (Tc=25°C)	150	1mA	500	15	5	6A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.15μs t_{stg}<1.5μs							211	
〃 3321	〃	〃	〃	500	400	15A	100W (Tc=25°C)	150	1mA	500	15	5	6A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.15μs t_{stg}<1.5μs							102	
〃 3322	日立	SW	Si.T	900	800	5A	80W (Tc=25°C)	150	100	750	25	5	500			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							373	
★ 〃 3323	東芝	RF.AF.LN	Si.E	60	50	150	200	150	0.1	60	350	6	2	10	−1	NF=1dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				150*	2	50	176	
〃 3324	〃	〃	〃	120	120	100	150	125	0.1	120	400	6	2	6	−1	NF=0.2dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				100*	3	18	176	2SA1312とコンプリ
〃 3325	〃	RF.AF	〃	50	50	500	200	150	0.1	50	120	1	100	6	−20					300*	7	20	176	2SA1313とコンプリ
〃 3326	〃	RF.SW	〃	50	20	300	200	150	0.1	50	600	2	4	2	−4	t_{on}<300ns, t_f<200ns t_{stg}<800ns				30*	4.8		176	
〃 3327	〃	RF.AF	〃	50	20	300	200	150	0.1	50	600	2	4	2	−4	t_{on}<300ns, t_f<200ns t_{stg}<800ns				30*	4.8		287	
〃 3328	〃	RF.SW	〃	80	80	2A	900	150	1	80	120	2	500	2	−500	t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<5μs				100*	30		241	
〃 3329	〃	RF.AF.LN	〃	80	80	100	400	125	0.1	80	400	6	2	6	−1	NF=0.2dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				40*	6.5	2	138	2SA1316とコンプリ
〃 3330	三洋	AF	Si.EP	60	50	200	300	150	0.1	40	300	6	1	6	−10					200*	3		92	2SA1317とコンプリ
〃 3331	〃	〃	〃	60	50	200	500	150	0.1	40	300	6	1	6	−10					200*	3		138	2SA1318とコンプリ
〃 3332	〃	RF	〃	180	160	700	700	150	0.1	120	250	5	100	10	−50					120*	8	$C_c r_{bb'}$ 25ps	138	2SA1319とコンプリ
〃 3333	東芝	RF	Si.T	250	250	50	600	150	0.1	200	80	20	25	10	−10					80*	2.1	25	138	2SA1320とコンプリ
〃 3334	〃	〃	〃	250	250	50	900	150	0.1	200	80	20	25	10	−10					100*	2.1	25	241	
★ 〃 3335	〃	〃	〃	250	250	50	1.2W	150	0.1	200	80	20	25	10	−10					100*	2.3	25	342	
〃 3336	日立	SW	Si.T	500	400	15A	100W (Tc=25°C)	150	50	400	20	5	7.5A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							373	
〃 3337	〃	RF	Si.E	20	15	100	400	150	0.5	15	100	5	50	5	−50	NF=2.9dB (5V, 10mA, 900MHz)	G_{pe}=8.6dB (5V, 50mA, 900MHz)			4400*	1.5	54*	138C	
〃 3338	〃	〃	〃	20	12	50	400	150	0.5	15	90	5	20	5	−20	NF=2dB (5V, 5mA, 900MHz)	G_{pe}=8.2dB (5V, 20mA, 900MHz)			4500*	1	48*	336	
★ 〃 3339	東芝	RF.AF	〃	60	50	150	150	125	0.1	60	350	6	2	10	−1					150*	2	50	176A	2SA1324とコンプリ
〃 3340	〃	〃	〃	120	120	100	150	125	0.1	120	350	6	2	6	−1					100*	3	18	176A	2SA1325とコンプリ
★ 〃 3341	〃	〃	〃	35	30	500	200	150	0.1	35	120	1	100	6	−20					300*	7	20	176A	2SA1326とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3342	日立	SW	Si. T	1300	500	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1300	15	5	300			t_{on}<1.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							102	
〃 3343	〃	〃	〃	1200	500	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1200	15	5	300			t_{on}<1.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							102	
★ 〃 3344	東芝	〃	〃	500	400	8 A	60W (Tc=25°C)	150	100	400	17	5	4 A			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							51	
〃 3345	〃	〃	Si. E	60	50	12A	40W (Tc=25°C)	150	10	60	120	1	1 A			t_{on}<0.6μs, t_f<0.6μs t_{on}< 3 μs							268	
〃 3346	〃	〃	〃	80	80	12A	40W (Tc=25°C)	150	10	80	120	1	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							268	
〃 3347	日電	PA	〃	45	45	2.4A	29.2W (Tc=25°C)	200	1 mA	30	15~170	3	2.4A			P_o=5.6W (f=2.2GHz, V_{CC}=20V, P_i=1 W)							352	
〃 3348	〃	〃	〃	45	45	3.6A	38.9W (Tc=25°C)	200	2 mA	30	15~170	3	2.6A			P_o=11.2W (f=2.2GHz, V_{CC}=20V, P_i=2 W)							352	
〃 3349	〃	〃	〃	45	20	600	10.9W (Tc=25°C)	200	250	30	70	5	100			P_o= 1 W (f= 2 GHz, V_{CC}=15V, P_i=0.13W)					< 2		118A	
〃 3350	〃	〃	〃	45	45	1.2A	17.5W (Tc=25°C)	200	500	30	70	5	200			P_o=3.2W (f= 3 GHz, V_{CC}=15V, P_i=0.5W)					<5.5		118B	
〃 3351	〃	〃	〃	45	45	2.4A	29.2W (Tc=25°C)	200	1 mA	30	70	5	400			P_o=5.4W (f= 3 GHz, V_{CC}=15V, P_i=1.3W)					< 9		118B	
〃 3352	松下	SW	Si.TMe	800	500	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	100	800	13	5	1 A	10	−200	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs				>2.5*			364	
〃 3353	〃	〃	〃	800	500	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	800	13	5	3 A	10	−500	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs				> 3*			364	
〃 3354	〃	RF	Si. EP	30	20	50	300	125	0.1	10	100	10	2	10	−15					1200*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 10ps	376	
〃 3355	日電	〃	Si. E	20	12	100	600	150	1	10	120	10	20	10	−20	$\|S_{21e}\|^2$=9.5dB (10V, 20mA, 1GHz)	NF=1.1dB (10V, 7mA, 1GHz)			6500*	Cre 0.65		138C	
〃 3356	〃	〃	〃	20	12	100	200	150	1	10	120	10	20	10	−20	$\|S_{21e}\|^2$=11.5dB (10V, 20mA, 1GHz)	NF=1.1dB (10V, 7mA, 1GHz)			7000*	Cre 0.55		176	
〃 3357	〃	〃	〃	20	12	100	2 W	150	1	10	120	10	20	10	−20	$\|S_{21e}\|^2$= 9 dB (10V, 20mA, 1GHz)	NF=1.1dB (10V, 7mA, 1GHz)			6500*	Cre 0.65		336	
〃 3358	〃	〃	〃	20	12	100	250	150	1	10	120	8	20	10	−20	$\|S_{21e}\|^2$=13dB (10V, 20mA, 1GHz)	NF=1.1dB (10V, 7mA, 1GHz)			7000*	Cre 0.5		210B	
〃 3359	ローム	RF. AF	Si. EP	80	80	300	400	125	0.5	80	82~390	3	100	5	−10					150*	5	$C_c r_{bb'}$ 60ps	138	
〃 3360	日電	SW	Si. E	200	200	50	200	150	0.1	200	90~400	10	10	10	−10	t_{on}<0.8μs, t_{off}<1.8μs t_{stg}<1.7μs				160*	2.8		176	2SA1330 とコンプリ
〃 3361	三洋	〃	Si. EP	60	50	150	150	125	0.1	40	250	6	1	6	− 1	t_d=40ns, t_{stg}=230ns t_r=80ns, t_f=160ns				100*	2.7		176	2SA1331 とコンプリ
〃 3362	日立	〃	Si. T	500	400	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	20	400	20	5	750			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							245	
〃 3363	〃	〃	〃	800	500	1 A	10W (Tc=25°C)	150	20	650	20	5	400			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							245	
★ 〃 3364	東芝	PA	Si. E	160	160	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	160	130	5	100	10	−100					200*	24	15	381	
〃 3365	日立	SW	Si. T	500	400	10A	80W (Tc=25°C)	150	50	400	18	5	5 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							373	
〃 3366	〃	〃	〃	150	100	5 A	40W (Tc=25°C)	150	5	120	150	2	2.5A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							268	
〃 3367	〃	〃	Si. E	120	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	0.5	100	120	1	2.5A			t_{on}=0.3μs, t_f=0.2μs t_{stg}=0.7μs							268	
〃 3368	松下	PA	Si. EP	36	16	100	500	150	100	10	100	10	50	10	−50	P_o=80mW (f=915MHz, V_{CE}=8V, P_i=5mW)				2500*	2.5		337B	
〃 3369	〃	〃	〃	36	16	300	2 W (Tc=25°C)	150	100	10	100	10	100	10	−100	P_o=350mW (f=915MHz, V_{CE}=8V, P_i=50mW)				3000*	4		337B	
〃 3370	東芝	〃	Si. T	200	200	15A	150W (Tc=25°C)	150	10	200	110	5	1 A	5	−1A					30*	270	10	125	2SA1333 とコンプリ
〃 3371	松下	SW	Si.TMe	800	500	10A	200W (Tc=25°C)	150	100	800	16	5	8 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							102	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3372	松下	PA	Si. EP	36	16	3 A	40W (Tc=25°C)	175	100	20	100	10	1 A			P_o= 8 W (f=915MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=2.5W)							374	
〃 3373	日電	Osc	Si. E	30	14	20	200	125	0.1	12	200	10	5	10	−5	V_{osc}=70mV (10V, 5mA, 900MHz)				1500*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	23	
〃 3374	日立	RF	〃	20	20	20	150	150	0.1	20	100	10	2	10	−2	NF=2.2dB (10V, 2mA, 200MHz)				550*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176	
〃 3375	東芝	RF. AF	〃	30	25	800	600	150	0.1	30	200	1	100	5	−10					120*	12	25	138	2SA1334 とコンプリ
〃 3376	〃	SW	Si. T	900	800	3 A	60W (Tc=25°C)	150	100	800	15	5	800			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 4 μs							203	
〃 3377	ローム	RF. AF	Si. EP	40	32	1 A	600	125	0.5	20	180	3	100	5	−50					150*	15	$C_c r_{bb'}$ 80ps	138	2SA1515 とコンプリ
〃 3378	東芝	RF. AF. LN	Si. E	120	120	100	200	125	0.1	120	350	6	2	6	−1	NF=0.2dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				100*	3	15	287	
〃 3379	三菱	PA	Si. EP	20	9	1.5A	10W (Tc=25°C)	175	300	10	50					P_o= 3 W (f=520MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=0.6W)							385	
〃 3380	日立	RF	Si. T	300	300	100	500	150	1	250	100	20	20	20	−20					80*	3	10*	336	
〃 3381	東芝	RF. AF. LN	Si. E	80	80	100	200/unit	125	0.1	80	400	6	2	10	−10	NF=0.2dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				170*	3.6	20	386	
〃 3382	三洋	〃	Si. EP	60	50	200	500	150	0.1	40	100~560	6	1	6	−10	NF=1.5dB (6V, 0.1mA, 100Hz)				250*	2.7	$C_c r_{bb'}$ 80ps	138	2SA1391 とコンプリ
〃 3383	〃	RF. AF	〃	60	50	200	500	150	0.1	40	100~560	6	1	6	−10					250*	2.7	$C_c r_{bb'}$ 80ps	138	2SA1392 とコンプリ
〃 3384	東芝	SW	Si. E	500	400	15A	120W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	10A			t_r<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							102	
〃 3385	〃	〃	〃	500	400	15A	120W (Tc=25°C)	150	100	500	12	5	10A			t_r<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 1 μs							102	
〃 3386	日立	〃	Si. T	80	50	3 A	10W (Tc=25°C)	150	10	80	160	1	1.5A			t_{on}< 0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs							377	
〃 3387	〃	〃	〃	1200	500	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	800	15	5	300			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 6 μs							373	
〃 3388	〃	〃	〃	1200	500	5 A	50W (Tc=25°C)	150	50	600	20	5	300			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 5 μs							102	
★ 〃 3389	三菱	RF. AF. PA	Si. EP	20	16	2 A	700	150	0.2	16	300	4	100	2	−10					80*	28	$C_c r_{bb'}$ 250ps	138	
〃 3390	日立	RF	Si. E	55	50	100	300	150	0.5	18	260	12	2	12	−2					200*	1.8	100	378	
〃 3391	〃	〃	Si. EP	30	20	20	200	150	0.5	10	100	6	1	6	−5					940*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 15ps	378	
〃 3392	三洋	SW	〃	60	50	500	200	150	0.1	40	100~560	5	10	10	−50	t_{on}=70ns, t_f=70ns t_{stg}=400ns				300*	3.7		176	2SA1338 とコンプリ
〃 3393	〃	RF. AF. PA	〃	60	50	500	300	150	0.1	40	100~560	5	10	10	−50	t_{on}=70ns, t_f=70ns t_{stg}=400ns				300*	3.7		92	2SA1339 とコンプリ
★ 〃 3394	日立	RF	Si. E	55	50	100	500	150	0.5	18	230	12	2	12	−2					230*	1.8	100	379	
〃 3395	三洋	SW	Si. EP	50	50	100	200	150	0.1	40	200	5	5	10	−5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=47±15kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				250*	3.5		176	2SA1341 とコンプリ
〃 3396	〃	〃	〃	50	50	100	200	150	0.1	40	200	5	5	10	−5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=22± 7kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				250*	3.5		176	2SA1342 とコンプリ
〃 3397	〃	〃	〃	50	50	100	200	150	0.1	40	200	5	5	10	−5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=46±14kΩ, R_B/R_{BE}=2.0±0.2)				250*	3.5		176	2SA1343 とコンプリ
〃 3398	〃	〃	〃	50	50	100	200	150	0.1	40	200	5	5	10	−5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10± 3kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				250*	3.5		176	2SA1344 とコンプリ
〃 3399	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	200	5	5	10	−5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=47±15kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				250*	3.7		92	2SA1345 とコンプリ
〃 3400	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	200	5	5	10	−5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=22± 7kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				250*	3.7		92	2SA1346 とコンプリ
〃 3401	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	200	5	5	10	−5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=46±14kΩ, R_B/R_{BE}=2.0±0.2)				250*	3.7		92	2SA1347 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3402	三洋	SW	Si.EP	50	50	100	300	150	0.1	40	200	5	5	10	−5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10±3kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)				250*	3.7		92	2SA1348とコンプリ
〃 3403	松下	〃	Si.TP	500	400	2A	25W (T_c=25°C)	150	100	500	15	5	1A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							363	
〃 3404	三菱	PA	Si.EP	20	9	1A	5W (T_c=25°C)	175	200	10	50	5	100			P_o=1.7W (f=175MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=80mW)							385	
〃 3405	東芝	SW	Si.T	900	800	800	20W (T_c=25°C)	150	100	800	20	5	300			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs							344	
〃 3406	松下	PA	Si.EP	36	16	3A	40W (T_c=25°C)	150	500	20	100	10	1A	10	−500	P_o=8W (f=915MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=2.5W)				2500*	30		345A	
〃 3407	〃	〃	〃	36	16	2A	20W (T_c=25°C)	150	500	20	100	10	500	10	−500	P_o=3.5W (f=915MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=1W)				2500*	20		345A	
〃 3408	〃	RF	Si.T	300	300	100	10W (T_c=25°C)	150	1	100	110	10	5	10	−10					80*	4	30	361	
〃 3409	サンケン	SW	Si.TP	900	800	2A	80W (T_c=25°C)	150	100	800	15	4	500			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3.8μs							324	
〃 3410	日電	RF	Si.E	35	18	2A	22W (T_c=25°C)	200	250	20	20~200	10	400			P_o=7.2W (f=500MHz, V_{CC}=9.6V, P_i=1.6W)					C_{re} 15		43	
〃 3411	日立	SW	Si.T	800	400	10A	50W (T_c=25°C)	150	500	500	20	5	1A			t_{on}<1μs, t_f<0.5μs t_{stg}<4μs							102	
〃 3412	〃	〃	〃	1300	500	8A	50W (T_c=25°C)	150	500	1300	20	5	1A			t_{on}<1μs, t_f<0.5μs t_{stg}<4μs							102	
〃 3413	〃	RF	Si.E	40	30	100	300	150	0.5	18	220	12	2	12	−2					200*	2	100	378	
★ 〃 3414	〃	〃	〃	40	30	100	400	150	0.5	18	220	12	2	12	−2					200*	2	100	379	
〃 3415	ローム	〃	Si.TP	300	300	100	600	125	0.5	200	82	10	10	30	−20					80*	4	100	138	
〃 3416	三洋	PA	Si.EP	200	200	100	1.2W	150	0.1	150	100	10	10	30	−10					70*	1.7	$C_c r_{bb'}$ 10ps	296	2SA1352とコンプリ
〃 3417	〃	〃	〃	300	300	100	1.2W	150	0.1	150	100	10	10	30	−10					70*	2.6	$C_c r_{bb'}$ 18ps	296	2SA1353とコンプリ
〃 3418	〃	〃	〃	400	400	100	1.2W	150	0.1	150	100	10	10	30	−10					100*	3.3	$C_c r_{bb'}$ 20ps	296	
〃 3419	東芝	RF	〃	40	40	800	5W (T_c=25°C)	150	0.1	40	120	2	50	2	−50					100*	20	25	384	2SA1356とコンプリ
〃 3420	〃	〃	〃	50	20	5A	10W (T_c=25°C)	150	0.1	40	300	2	500	2	−500					100*	40	16	384	2SA1357とコンプリ
〃 3421	〃	〃	〃	120	120	1A	10W (T_c=25°C)	150	0.1	120	150	5	100	5	−100					120*	15	3	384	2SA1358とコンプリ
〃 3422	〃	〃	〃	40	40	3A	10W (T_c=25°C)	150	0.1	40	150	2	500	2	−500					100*	35	10	384	2SA1359とコンプリ
〃 3423	〃	〃	〃	150	150	50	5W (T_c=25°C)	150	0.1	150	150	5	10	5	−10					200*	1.8	50	384	
〃 3424	〃	〃	Si.T	250	250	50	1.5W	150	0.1	200	80	20	25	10	−10					100*	2.3	25	384	
〃 3425	〃	SW	〃	500	400	800	10W (T_c=25°C)	150	100	400	55	5	100			t_r<1μs, t_f<1.5μs t_{stg}<2.5μs							384	
〃 3426	〃	RF	Si.E	15	15	800	200	150	0.1	15	350	1	100	5	−10					120*	13	20	176	
〃 3427	新電元	SW	Si.EP	50	30	7A	50W (T_c=25°C)	150	10	50	>100	2	4A			t_{on}<0.2μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2μs				10*			268	T7S3
〃 3428	〃	〃	〃	60	40	10A	50W (T_c=25°C)	150	10	50	>85	2	5A			t_{on}<0.2μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2μs				10*			268	T10S4
〃 3429	東芝	RF	Si.E	17	12	70	150	125	1	10	100	10	20	10	−20	NF=1.7dB (10V, 5mA, 1GHz)				5000*	0.85	70*	176	
〃 3430	日電	SW	Si.T	500	400	2A	20W (T_c=25°C)	150	100	400	30	5	1A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							370	
〃 3431	〃	〃	〃	500	400	5A	40W (T_c=25°C)	150	100	400	30	5	2.5A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							370	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3432	日電	SW	Si. T	500	400	7 A	60W (Tc=25°C)	150	100	400	30	5	3.5A			t_{on}<0.5μs, t_{stg}<1.5μs	t_f<0.3μs						370	
〃 3433	〃	〃	〃	500	400	10A	60W (Tc=25°C)	150	100	400	30	5	1 A			t_{on}<0.5μs, t_{stg}<1.5μs	t_f<0.3μs						370	
〃 3434	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	30	5	1 A	10	−1A	t_{on}<0.5μs, t_{stg}<1.5μs	t_f<0.3μs			30 *	120		162	
〃 3435	〃	〃	〃	500	400	15A	120W (Tc=25°C)	150	100	400	10〜60	5	1.5A	10	−1.5A	t_{on}<0.5μs, t_{stg}<1.5μs	t_f<0.3μs			30 *	170		162	
〃 3436	〃	〃	〃	500	500	20A	200W (Tc=25°C)	150	10	500	20	1	20A			t_{on}< 1 μs, t_{stg}<1.5μs	t_f<0.2μs						266	
〃 3437	東芝	RF. SW	Si. E	40	15	200	150	125	0.1	40	100	1	10	10	−10	t_{on}<100ns, t_{stg}<30ns	t_{off}<70ns			400 *	4	40	176	
〃 3438	三菱	RF. AF. PA	Si. EP	100	100	500	500	150	0.5	50	150	10	10	10	−10					130 *	6.5	$C_c r_{bb'}$ 20ps	336	2SA1368 とコンプリ
〃 3439	〃	〃	〃	30	20	1.5A	500	150	0.1	20	1300	6	500	10	−10					130 *	17	$C_c r_{bb'}$ 440ps	336	2SA1369 とコンプリ
〃 3440	〃	〃	〃	25	20	700	150	125	1	25	300	4	100	6	−10					180 *	15	$C_c r_{bb'}$ 100ps	176	2SA1365 とコンプリ
〃 3441	〃	〃	〃	55	50	300	150	125	1	25	250	4	100	6	−10					150 *	10	$C_c r_{bb'}$ 100ps	176	2SA1366 とコンプリ
〃 3442	〃	RF. AF	〃	50	50	100	300	125	0.5	50	300	6	1	6	− 1					100 *	2.5	$C_c r_{bb'}$ 300ps	175	
〃 3443	〃	RF. AF. PA	〃	20	16	2 A	500	150	0.2	16	300	4	100	2	−10					80 *	28	$C_c r_{bb'}$ 250ps	336	2SA1363 とコンプリ
〃 3444	〃	〃	〃	60	60	1 A	500	150	0.2	50	150	4	100	2	−10					120 *	14	$C_c r_{bb'}$ 48ps	336	2SA1364 とコンプリ
〃 3445	東芝	RF	Si. E	15	7.5	80	150	125	0.1	10	70	3	50	5	−30	NF=2.3dB (5 V, 10mA, 1 GHz)				7000*	1.2	70 *	176	
〃 3446	三洋	SW	Si. TP	800	500	3 A	40W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	1.5A	10	−300	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			18 *			268	
〃 3447	〃	〃	〃	800	500	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	3 A	10	−600	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			18 *			268	
〃 3448	〃	〃	〃	800	500	4 A	60W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	1.5A	10	−300	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			18 *			346	
〃 3449	〃	〃	〃	800	500	7 A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	3 A	10	−800	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			18 *			346	
〃 3450	〃	〃	〃	800	500	10A	90W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	4 A	10	−800	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			18 *			346	
〃 3451	〃	〃	〃	800	500	15A	100W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	6 A	10	−1.2A	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			18 *			346	
〃 3452	〃	〃	〃	800	500	7 A	70W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	3 A			t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs						102	
〃 3453	〃	〃	〃	800	500	10A	100W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	4 A			t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs						102	
〃 3454	〃	〃	〃	800	500	15A	120W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	6 A			t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs						102	
〃 3455	〃	〃	〃	800	500	25A	160W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	12A	10	−2.4A	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			18 *			102	
〃 3456	〃	〃	〃	1100	800	1.5A	40W (Tc=25°C)	150	10	800	12	5	100	10	−100	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			15 *			268	
〃 3457	〃	〃	〃	1100	800	3 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	12	5	200	10	−200	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			15 *			268	
〃 3458	〃	〃	〃	1100	800	3 A	80W (Tc=25°C)	150	10	800	12	5	200	10	−200	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			15 *			346	
〃 3459	〃	〃	〃	1100	800	4.5A	90W (Tc=25°C)	150	10	800	12	5	400	10	−400	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			15 *			346	
〃 3460	〃	〃	〃	1100	800	6 A	100W (Tc=25°C)	150	10	800	12	5	400	10	−400	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			15 *			346	
〃 3461	〃	〃	〃	1100	800	8 A	120W (Tc=25°C)	150	10	800	12	5	3 A	10	−600	t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs			15 *			346	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC3462	三洋	SW	Si.TP	1100	800	4.5A	100W (Tc=25°C)	150	10	800	12	5	1.5A	10	−800	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 3 μs				15 *			102	
★	〃 3463	〃	〃	〃	1100	800	6 A	120W (Tc=25°C)	150	10	800	12	5	2 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 3 μs							102	
★	〃 3464	〃	〃	〃	1100	800	8 A	130W (Tc=25°C)	150	10	800	12	5	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 3 μs							102	
★	〃 3465	〃	〃	〃	1100	800	12A	160W (Tc=25°C)	150	10	800	12	5	4 A	10	−800	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 3 μs				15 *	240		102	
★	〃 3466	〃	〃	〃	1200	650	8 A	120W (Tc=25°C)	150	10	650	10	5	4 A	10	−1A	t_{on}< 1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}< 4 μs				5 *	120		346	
★	〃 3467	〃	PA	Si.EP	200	200	100	1 W	150	0.1	150	100	10	10	30	−10					150 *	1.7	$C_c r_{bb'}$ 10ps	294	2SA1370 とコンプリ
★	〃 3468	〃	〃	〃	300	300	100	1 W	150	0.1	150	100	10	10	30	−10					150 *	2.6	$C_c r_{bb'}$ 18ps	294	2SA1371 とコンプリ
	〃 3469	〃	RF	〃	400	400	100	1 W	150	0.1	150	100	10	10	30	−10					150 *	3.3	$C_c r_{bb'}$ 20ps	294	
	〃 3470	日立	〃	Si.E	55	50	100	300	150	0.5	18	650	12	2	12	− 2					230 *	1.8	$C_c r_{bb'}$ 40ps	378	
	〃 3471	〃	〃	〃	60	50	200	400	150	0.1	50	360	6	1	6	−10					250 *	2.5	1 k *	138B	
	〃 3472	富士電	SW	Si.TP	900	650	3 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	20	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f<1.5μs t_{stg}< 4 μs							211	ダーリントン
	〃 3473	日立	〃	Si.E	50	50	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	40	180	1	200	4	−20	t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs				50 *	100		268	
	〃 3474	東芝	〃	〃	80	80	2 A	20W (Tc=25°C)	150	1	80	1000	1	400			t_{on}< 5 μs, t_f< 4 μs t_{stg}<10μs							344	
	〃 3475	〃	〃	Si.T	80	60	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	110	4	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs							381	
★	〃 3476	三菱	PA	Si.EP	35	17	1.5A	10W (Tc=25°C)	175	300	15	50	10	100			P_o=3.5W (f=520MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=0.3W)							385	
	〃 3477	松下	RF	〃	15	12	30	350	125	0.1	10	150	10	10	10	−10					4500*	0.6	15	337B	
	〃 3478	日電	AF.PA.SW	Si.E	200	180	100	750	150	0.1	200	135~600	10	10	10	−10	t_{on}=0.15μs t_{off}=1.6μs				160 *	2.8		138	2SA1376 とコンプリ ○
	〃 3479	三洋	SW	Si.TP	1500	800	2.5A	80W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	500	10	−500	t_{stg}< 3 μs t_f<0.3μs				3 *			346	ダンパ内蔵 水平偏向用
	〃 3480	〃	〃	〃	1500	800	3.5A	80W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	500	10	−500	t_{stg}< 3 μs t_f<0.3μs				3 *			346	ダンパ内蔵 水平偏向用
	〃 3481	〃	〃	〃	1500	800	5 A	120W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A	10	−1A	t_{stg}< 3 μs t_f<0.3μs				3 *			346	ダンパ内蔵 水平偏向用
	〃 3482	〃	〃	〃	1500	800	6 A	120W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A	10	−1A	t_{stg}< 3 μs t_f<0.3μs				3 *			346	ダンパ内蔵 水平偏向用
	〃 3483	〃	〃	〃	1500	800	2.5A	80W (Tc=25°C)	150	10	800	25	5	500	10	−500	t_{stg}< 3 μs t_f<0.3μs				3 *			346	水平偏向用
	〃 3484	〃	〃	〃	1500	800	3.5A	80W (Tc=25°C)	150	10	800	25	5	500	10	−500	t_{stg}< 3 μs t_f<0.3μs				3 *			346	水平偏向用
	〃 3485	〃	〃	〃	1500	800	5 A	120W (Tc=25°C)	150	10	800	25	5	1 A	10	−1A	t_{stg}< 3 μs t_f<0.3μs				3 *			346	水平偏向用
	〃 3486	〃	〃	〃	1500	800	6 A	120W (Tc=25°C)	150	10	800	25	5	1 A	10	−1A	t_{stg}< 3 μs t_f<0.3μs				3 *			346	水平偏向用
★	〃 3487	東芝	RF.AF	Si.E	50	50	100	300	125	0.1	50	400	6	2	6	− 2					150 *	1.6	50	138	2SA1377 とコンプリ
	〃 3488	〃	RF.AF.PA	〃	35	30	500	300	150	0.1	35	120	1	100	6	−20					300 *	7	$C_c r_{bb'}$ 50ps	287	
	〃 3489	日立	SW	Si.T	900	800	800	10W (Tc=25°C)	150	20	750	20	5	300			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 7 μs							377	
	〃 3490	〃	〃	〃	900	800	3 A	40W (Tc=25°C)	150	50	750	18	5	300			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs							268	
	〃 3491	〃	〃	〃	1000	400	4 A	60W (Tc=25°C)	150	50	800	25	5	1 A			t_{on}<0.7μs, t_{off}< 5 μs t_{stg}< 4 μs							268	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3492	日立	SW	Si. E	50	50	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	50	160	1	200	4	−20	t_{on}<0.5μs, t_{off}<1.5μs t_{stg}<1μs				50*	100		268	
〃 3493	〃	RF	〃	15	12	20	150	150	1	12	110	4	2	4	−2	NF=2.3dB (6V, 2mA, 200MHz)				>700*	C_{re} 0.2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176	
〃 3494	〃	〃	Si. EP	30	30	100	300	150	0.5	18	100	12	2	12	−2					230*	1.8	40	378	
〃 3495	三洋	RF. AF	〃	120	100	50	500	150	0.1	80	1000	5	10	10	−10					170*	1.8		138	2SA1437とコンプリ
〃 3496	松下	SW	Si.TMe	900	800	500	25W (Tc=25°C)	150	100	900	10	5	100			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							363	
〃 3497	東芝	〃	Si. E	500	400	6 A	30W (Tc=25°C)	150	100	500	13	5	3 A			t_r<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							381	
〃 3498	〃	〃	〃	500	400	30A	150W (Tc=25°C)	150	100	500	15	10	15A			t_r<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2μs							152	
〃 3499	〃	〃	〃	500	450	30A	150W (Tc=25°C)	150	100	500	13	5	15A			t_r<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2μs							152	
★ 〃 3500	日電	RF	〃	50	30	4 A	32W (Tc=25°C)	200	400	30	60	10	600			P_o=4.8W (f=860MHz, Vcc=24V, P_i=0.4W)					8		375B	
〃 3501	日立	Conv. Osc	〃	20	11	50	200	125	0.5	16	80	10	5	10	−5	G_{ce}=17dB f_{if}=30MHz (Vcc=10V, Ic=3mA, f=900MHz)				3500*	1	$C_c r_{bb'}$ 9 ps	240B	
〃 3502	三洋	PA	Si. EP	200	200	100	1.2W	150	0.1	150	100	10	10	30	−10					150*	1.7		296	2SA1380とコンプリ
〃 3503	〃	〃	〃	300	300	100	1.2W	150	0.1	200	100	10	10	30	−10					150*	2.6		296	2SA1381とコンプリ
〃 3504	〃	〃	〃	70	60	50	900	150	0.1	40	200	10	10	10	−10					500*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	294	
〃 3505	富士電機	SW	Si. TP	900	700	6 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	20	5	2 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<5μs							211	
〃 3506	松下	〃	〃	1000	800	3 A	70W (Tc=25°C)	150	50	1000	>6	5	2 A	5	−200	t_{on}<1μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs				>4*			82	
〃 3507	〃	〃	〃	1000	800	5 A	80W (Tc=25°C)	150	50	400	>6	5	3 A	5	−500	t_{on}<1μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs				>6*			82	
〃 3508	〃	〃	〃	800	800	6 A	80W (Tc=25°C)	150	100	800	>7	2	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.7μs t_{stg}<3μs							82	
〃 3509	〃	〃	〃	800	800	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	800	>7	2	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.7μs t_{stg}<3μs							82	
〃 3510	日立	RF	Si. E	20	12	50	600	150	0.5	12	90	5	20	5	−20	NF=2.2dB (5V, 5mA, 900MHz) G_{pe}=10.5dB (5V, 20mA, 900MHz)				4500*	0.9	53*	138C	
〃 3511	〃	〃	〃	15	11	100	200	150	1	12	120	5	20	5	−20	NF=1.5dB (5V, 5mA, 900MHz) G_{pe}=11dB (5V, 20mA, 900MHz)				6000*	1	50*	240C	
〃 3512	〃	〃	〃	15	11	100	600	150	1	12	120	5	20	5	−20	NF=1.6dB (5V, 5mA, 900MHz) G_{pe}=10.5dB (5V, 20mA, 900MHz)				6000*	1.2	50*	138C	
〃 3513	〃	〃	〃	15	11	100	150	150	1	12	120	5	20	5	−20	NF=1.6dB (5V, 5mA, 900MHz) G_{pe}=10dB (5V, 20mA, 900MHz)				6000*	1	50*	176	
〃 3514	日電	PA	〃	180	180	100	10W (Tc=25°C)	150	1	180	190	5	1	10	−20	NF=4dB (10V, 1mA, 1kHz)				200*	3.2	32*	268	2SA1383とコンプリ
〃 3515	東芝	RF	Si. T	300	300	100	1 W	150	0.1	300	90	10	20	10	−20					80*	3	15	336	
〃 3516	オリジン	SW	〃	1200	800	30A	200W (Tc=25°C)	150	50	960	15	5	10A			t_{on}<1.5μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs							121	
〃 3517	〃	〃	〃	1200	800	50A	300W (Tc=25°C)	150	50	960	15	5	15A			t_{on}<3μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs							121	
〃 3518	日電	PA. SW	Si. E	60	60	5 A	10W (Tc=25°C)	150	10	50	200	1	2 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2.5μs							186	2SA1385とコンプリ
〃 3519	サンケン	PA	Si. EP	160	160	15A	130W (Tc=25°C)	150	100	160	80	4	5 A	12	−2A					50*	250	10	324	2SA1386とコンプリ ○
〃 3520	〃	SW	Si. TP	500	400	18A	130W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	10A			t_{on}<0.7μs, t_f<0.7μs t_{stg}<3μs							324	
〃 3521	日立	〃	Si. E	40	15	100	100	125	0.25	20	80	0.5	1			t_{on}<100ns, t_{off}<150ns t_{stg}<60ns							176	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3522	TDK	SW	Si.TP	500	400	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	400	>20	5	1 A	t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2.5μs									268	
〃 3523	〃	RF	Si.EP	100	60	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	>60	5	500	$V_{CE(sat)}$<0.5V (I_C=3 A, I_B=0.3A) $V_{BE(sat)}$<1.5V									268	
〃 3524	〃	SW	〃	150	100	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	100	5	1 A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs									268	
〃 3525	〃	〃	Si.TP	500	400	5 A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	>20	5	5 A	t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2 μs									102	
〃 3526	松下	RF	Si.EP	100	70	100	1 W	150	100	100	>15	5	100	10	−20					250*	3		294	
〃 3527	〃	SW	Si.TP	500	400	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	13	5	8 A	t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2.5μs									82	
〃 3528	〃	〃	〃	500	400	20A	125W (Tc=25°C)	150	100	500	13	5	10A	t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2.5μs									82	
〃 3529	日電	〃	Si. T	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	10	400	30	5	500	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs									268	
★ 〃 3530																								
〃 3531	日電	SW	Si. T	1000	800	3 A	50W (Tc=25°C)	150	100	800	20	5	200	t_{on}<1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3 μs									268	
〃 3532	〃	〃	〃	1000	800	4 A	60W (Tc=25°C)	150	100	800	20	5	300	t_{on}<1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3 μs									370	
〃 3533	〃	〃	〃	1000	800	3 A	70W (Tc=25°C)	150	100	800	20	5	200	t_{on}<1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3 μs									162	
〃 3534	〃	〃	〃	1000	800	4 A	80W (Tc=25°C)	150	100	800	20	5	300	t_{on}<1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3 μs									162	
〃 3535	〃	〃	〃	1000	800	6 A	100W (Tc=25°C)	150	100	800	10～30	5	500	t_{on}<1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3 μs									162	
〃 3536	〃	〃	〃	1000	800	8 A	120W (Tc=25°C)	150	100	800	10～30	5	800	t_{on}<1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3 μs									162	
〃 3537	〃	RF	Si. E	50	50R	3 A	50W (Tc=25°C)	200	2 mA	30	60	10	1 A	P_o=2.0W, η=60% (f=900MHz, V_{CC}=24V, P_i=2.5W)							Cre 25		375A	
〃 3538	〃	〃	〃	50	50R	6 A	120W (Tc=25°C)	200	4 mA	30	60	10	2 A	P_o=40W, η=60% (f=900MHz, V_{CC}=24V, P_i=6.3W)							Cre 50		375A	
〃 3539	〃	〃	〃	50	50	9 A	170W (Tc=25°C)	200	8 mA	30	60	10	3 A	P_o=60W (f=900MHz, V_{CC}=24V, P_i=10W)							Cre 80		375A	
〃 3540	東芝	SW	〃	100	80	5 A	25W (Tc=25°C)	150	1	100	150	1	1 A	t_{on}<0.3μs, t_f<0.2μs t_{stg}<2 μs									381	
〃 3541	日電	PA	〃	35	18	2 A	19.5W (Tc=25°C)	200	150	20	60	10	300	P_o=5.6W, η=55% (f=1300MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=1W)							15		375B	
〃 3542	〃	〃	〃	35	18	6 A	50W (Tc=25°C)	200	450	20	60	10	600	P_o=15.8W, η=60% (f=1300MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=4W)							50		375B	
★ 〃 3543																								
〃 3544	日電	Conv. Osc	Si. E	30	15	50	250	150	0.1	12	100	10	5	10	−5					2000*	0.55	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	138C	
〃 3545	〃	〃	〃	30	15	50	150	125	0.1	12	100	10	5	10	−5					2000*	Cre 0.48	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	176	
〃 3546	東芝	PA	Si. T	160	160	12A	120W (Tc=25°C)	150	10	160	100	5	1 A	5	−1A					30*	250	10	125	2SA1389とコンプリ
〃 3547	〃	RF	Si. E	20	15	30	150	125	0.1	10	120	10	5	10	−10	NF=2 dB (10V, 5 mA, 1 GHz)				4000*	1.05	70*	176	
〃 3548	〃	〃	〃	20	15	30	150	125	0.1	10	120	10	5	10	−10	NF=2 dB (10V, 5 mA, 1 GHz)				4000*	1	70*	347C	
〃 3549	富士電機	SW	Si.TP	900	800	3 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	12	5	1 A	t_{on}<1 μs, t_f<0.8μs t_{stg}<4 μs									268	
〃 3550	〃	〃	〃	900	800	3 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	12	5	1 A	t_{on}<1 μs, t_f<0.8μs t_{stg}<4 μs									211	
〃 3551	〃	〃	〃	900	800	5 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	12	5	2 A	t_{on}<1 μs, t_f<0.8μs t_{stg}<4 μs									211	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC3552	三洋	SW	Si. T	1100	800	12A	150W (Tc=25°C)	150			>10	5	800	10	−800	t_f<0.3μs				15 *			346	
〃 3553	日立	AF	Si. E	35	35	500	300	150	0.5	20	160	3	10	3	−10					120 *	7	9 *	378	
〃 3554	日電	SW	Si. T	300	300	200	400	150	0.1	200	150	10	10	30	−10	t_r<0.9μs, t_f<0.9μs t_{stg}<1.9μs				50 *	2.8		336	
〃 3555	日立	〃	〃	900	800	500	20W (Tc=25°C)	150	20	750	15	5	100			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 4 μs							377	
〃 3556	〃	〃	〃	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	80	150	1	200			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs							268	
〃 3557	〃	〃	〃	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	80	150	1	200			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							268	
〃 3558	東芝	〃	〃	100	60	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	100	110	4	1 A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs									268	
〃 3559	〃	〃	〃	900	800	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	800	15	5	800	t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 4 μs									381	
〃 3560	〃	〃	Si. E	500	400	2 A	20W (Tc=25°C)	150	100	500	14	5	800	t_r<0.3μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs									381	
〃 3561	〃	〃	〃	500	450	2 A	20W (Tc=25°C)	150	100	500	14	5	800	t_r<0.3μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs									381	
〃 3562	〃	〃	〃	500	400	10A	40W (Tc=25°C)	150	100	500	14	5	4 A	t_r<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs									381	
〃 3563	〃	〃	〃	500	450	10A	40W (Tc=25°C)	150	100	500	14	5	4 A	t_r<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs									381	
〃 3564	日電	PA	〃	120	120	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	120	150	5	300	5	−200					200 *	19		96	2SA1393 とコンプリ
〃 3565	〃	〃	Si. T	300	300	200	15W (Tc=25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	−10					80 *	4		96	
〃 3566	〃	SW	Si. E	150	60	5 A	25W (Tc=25°C)	150	10	60	40~200	5	3 A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs									96	2SA1394 とコンプリ
〃 3567	〃	〃	〃	150	100	3 A	15W (Tc=25°C)	150	10	100	40~200	5	1 A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs									96	2SA1395 とコンプリ
〃 3568	〃	〃	〃	150	100	10A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	40~200	5	3 A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs									96	2SA1396 とコンプリ
〃 3569	〃	〃	Si. T	500	400	2 A	15W (Tc=25°C)	150	10	400	20~80	5	100	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs									96	2SA1397 とコンプリ
〃 3570	〃	〃	〃	500	400	5 A	25W (Tc=25°C)	150	10	400	20~80	5	500	t_{on}< 1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}<7.5μs									96	
〃 3571	〃	〃	〃	500	400	7 A	30W (Tc=25°C)	150	10	400	20~80	5	1 A	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs									96	
〃 3572	〃	〃	〃	500	400	10A	30W (Tc=25°C)	150	10	400	35	5	1 A	t_{on}< 1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}<2.5μs									96	
〃 3573	〃	〃	〃	500	400	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	400	30	5	500	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs									96	
〃 3574	〃	〃	〃	500	400	7 A	30W (Tc=25°C)	150	10	400	30	5	700	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs									96	
〃 3575	〃	〃	〃	500	400	10A	30W (Tc=25°C)	150	100	400	30	5	1 A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs									96	
〃 3576	三洋	AF	Si.EP	30	25	300	300	150	0.1	20	1500	5	10										92	
〃 3577	松下	SW	Si.TP	1000	700	5 A	80W (Tc=25°C)	150	50	1000	25	5	10	t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs									82	
〃 3578	日立	〃	Si.EP	40	15	100	100	125	0.25	20	80	0.5	1	t_{on}<40ns, t_{off}≤70ns t_{stg}<30ns									176	
〃 3579	新電元	〃	Si.TP	800	800	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	800	10	2	3 A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.7μs t_{stg}< 3 μs						8 *			268	ダーリントン
〃 3580	三菱	AF	Si.EP	25	20	700	900	150	0.2	25	300	4	100	6	−10					180 *	11	$C_c r_{bb'}$ 100pls	6	
〃 3581	〃	〃	〃	65	60	400	900	150	0.2	55	250	4	100	6	−10					130 *	6	$C_c r_{bb'}$ 50pls	6	2SA1399 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC3582	日電	RF	Si. E	20	10	65	600	150	1	10	100	8	20	8	−20	NF=1.2dB (8V, 7mA, 1GHz)				8000*	C_{re} 0.4	5	138C	
〃 3583	〃	〃	〃	20	10	65	200	150	1	10	50~250	8	20	8	−20	NF=1.2dB (8V, 7mA, 1GHz)				9000*	C_{re} 0.35	5	176	
〃 3584	〃	〃	〃	20	10	65	200	150	1	10	100	8	20	8	−20	NF=1.2dB (8V, 7mA, 1GHz)				9000*	C_{re} 0.25	5	210B	
〃 3585	〃	〃	〃	20	10	35	200	150	1	10	100	6	10	6	−10	NF=1.8dB (6V, 5mA, 2GHz)				10GHz*	C_{re} 0.3	5	176	
〃 3586	〃	〃	〃	20	10	35	250	150	0.1	10	100	6	10	6	−10	NF=1.8dB (6V, 5mA, 2GHz)				10GHz*	C_{re} 0.2	5	210B	
〃 3587	〃	〃	〃	20	10	35	580	200	1	10	100	6	10	6	−10	NF=1.7dB (6V, 5mA, 2GHz)				10GHz*	C_{re} 0.2	5	314	
〃 3588	〃	SW	Si. T	500	400	500	10W (T_c=25°C)	150	10	400	42	5	50	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<25μs									186	2SA1400とコンプリ
〃 3589	三洋	〃	Si.EP	250	100	7 A	40W (T_c=25°C)	150	100	150	40	1	5 A	10	−500	t_f<0.3μs				40 *			268	水平偏向用
〃 3590	〃	〃	〃	330	150	7 A	50W (T_c=25°C)	150	100	180	30	1	5 A	10	−500	t_f<0.3μs				40 *			268	水平偏向用
〃 3591	〃	〃	〃	400	200	7 A	50W (T_c=25°C)	150	100	250	30	1	5 A	10	−500	t_f<0.3μs				40 *			268	水平偏向用
〃 3592	日電	〃	Si. E	60	60	5 A	10W (T_c=25°C)	150	10	50	250	1	2 A	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs									185	
〃 3593	松下	〃	Si.TP	850	850S	25A	150W (T_c=25°C)	150	100	850	150	5	25A	t_{on}< 3 μs t_f< 1 μs t_{stg}<1.5μs									102	
〃 3594	日立	〃	Si. T	1400	650	8 A	50W (T_c=25°C)	150	100	1400	20	5	300	t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs									102	
〃 3595	三洋	RF	Si.EP	30	20	500	1.2W	150	0.1	20	90	5	50	5	−100					2000*	6	$C_c r_{bb'}$ 3 ps	296	
〃 3596	〃	〃	〃	80	60	300	1.2W	150	0.1	60	90	10	50	10	−100					700 *	3	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	296	
〃 3597	〃	〃	〃	80	60	500	1.2W	150	0.1	60	90	10	50	10	−100					800 *	3.4	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	296	
〃 3598	〃	〃	〃	120	120	200	1.2W	150	0.1	80	90	10	10	10	−150					500 *	2	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	296	
〃 3599	〃	〃	〃	120	120	300	1.2W	150	0.1	80	90	10	50	10	−50					500 *	2.9	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	296	
〃 3600	〃	〃	〃	200	200	100	1.2W	150	0.1	150	90	10	10	30	−30					400 *	1.8	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	296	2SA1406とコンプリ
〃 3601	〃	〃	〃	200	200	150	1.2W	150	0.1	150	90	10	10	30	−50					400 *	2.5	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	296	
〃 3602	東芝	〃	Si. P	25	20	20	200	125	0.1	10	100	10	2	10	− 2	G_{pb}=18dB (f=800MHz, V_{CC}=12V)				1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	347A	
〃 3603	日電	〃	Si. E	20	12	100	580	200	1	10	120	10	20	10	−20	NF=2.1dB (10V, 7mA, 2GHz)				7000*	C_{re} 0.5		314	
〃 3604	〃	〃	〃	20	16	65	580	200	1	10	100	8	20	8	−20	NF=1.6dB (8V, 7mA, 2GHz)				8000*	C_{re} 0.2		314	
〃 3605	東芝	〃	〃	20	12	80	600	125	1	10	100	10	20	10	−20	NF=1.1dB (10V, 5mA, 1GHz)				7000*	1	65 *	138C	
〃 3606	〃	〃	〃	20	12	80	150	125	1	10	100	10	20	10	−20	〃				6500*	1.3	60 *	176	
〃 3607	〃	〃	〃	20	12	80	300	125	1	10	100	10	20	10	−20	〃				6500*	1.2	85 *	336	
〃 3608	〃	〃	〃	20	12	80	200	125	1	10	100	10	20	10	−20	〃				7000*	1	55 *	347C	
〃 3609	〃	〃	〃	20	12	80	150	125	1	10	100	10	20	10	−20	〃				7000*	1	60 *	394A	
〃 3610	松下	RF	Si. E	110	100	150	10W (T_c=25°C)	150	10	35	40	5	100	10	−10					300 *	3	70	268	
〃 3611	〃		〃	110	100	150	1.2W	150	10	35	40	5	100	10	−10					300 *	3	70	222	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)		外形	備考
2SC3612	東芝	RF	Si.EP	180	150	500	20W (Tc=25°C)	150	1	150	100	10	100	10	−100					320*	11	15	268	
〃 3613	〃	〃	〃	50	18	300	10W (Tc=25°C)	150	1	20	60	10	50	10	−50					2500*	3.5	60	384	
〃 3614	日立	〃	Si.E	20	15	100	500	150	0.5	15	100	5	50			G_{pe}= 6 ～8.4dB (5V, 50mA, 900MHz)					1.8	55*	336	
〃 3615	日電	AF.SW	〃	50	50	300	750	150	0.1	50	800~3200	5	100	5	−100	t_{on}=0.15μs, t_{off}=1.1μs t_{stg}=0.75μs				220*	8		138	
〃 3616	〃	〃	〃	25	25	700	750	150	0.1	25	800~3200	2	300	5	−300	t_{on}=0.13μs, t_{off}=1.1μs t_{stg}=0.9μs				250*	10		138	
〃 3617	〃	〃	〃	50	50	300	2W (セラミック基板使用)	150	0.1	50	800~3200	5	100	5	−100	t_{on}=0.15μs, t_{off}=1.1μs t_{stg}=0.75μs				220*	8		336	
〃 3618	〃	〃	〃	25	25	700	2W (セラミック基板使用)	150	0.1	25	800~3200	2	300	5	−300	t_{on}=0.13μs, t_{off}=1.1μs t_{stg}=0.9μs				250*	10		336	
〃 3619	東芝	RF	Si.T	300	300	100	1.5W	150	1	240	60	10	20	10	−20					70*	3	15	384	
〃 3620	〃	〃	〃	300	300	150	1.5W	150	1	240	70	10	50	10	−30					110*	3.5	15	384	
〃 3621	〃	〃	Si.E	150	150	1.5A	1.5W	150	1	150	120	5	200	5	−200					140*	12	20	384	2SA1408とコンプリ
〃 3622	日電	AF.SW	〃	60	50	150	250	150	0.1	50	1800	5	1	5	−10	t_{on}=0.13μs, t_{off}=1.22μs t_{stg}=0.72μs				250*	3		138	
〃 3623	〃	〃	〃	60	50	150	250	150	0.1	50	1800	5	1	5	−10	t_{on}=0.13μs, t_{off}=1.22μs t_{stg}=0.72μs				250*	3		42	
〃 3624	〃	〃	〃	60	50	150	200	150	0.1	50	1800	5	1	5	−10	t_{on}=0.13μs, t_{off}=1.22μs t_{stg}=0.72μs				250*	3		176	
〃 3625	東芝	SW	Si.T	500	400	8A	60W (Tc=25°C)	150	100	400	17	5	4A										268	
〃 3626	〃	〃	〃	500	400	8A	40W (Tc=25°C)	150	100	400	17	5	4A										381	
〃 3627	〃	〃	〃	250	200	10A	40W (Tc=25°C)	150	100	200	30	5	5A										381	
〃 3628	三菱	PA	Si.EP	35	17	2A	20W (Tc=25°C)	175	500	25	50	10	100			P_o=6.5W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.25W)							385	
〃 3629	〃	〃	〃	20	9	1A	5W (Tc=25°C)	175	200	10	50	5	100			P_o=1.5W (f=520MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=0.2W)							385	
〃 3630	〃	〃	〃	35	17	1A	10W (Tc=25°C)	175	300	15	50	10	100			P_o=3.3W (f=520MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=0.3W)							385	
〃 3631	日電	SW	Si.T	500	400	2A	10W (Tc=25°C)	150	10	400	60	5	100	10	−100					50*	20		186	2SA1412とコンプリ
〃 3632	〃	〃	〃	600	600	1A	10W (Tc=25°C)	150	10	600	55	5	50							30*	14		186	2SA1413とコンプリ
〃 3633	三洋	〃	Si.TP	900	500	7A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	800			t_{on}<0.5μs, t_f<0.2μs t_{stg}< 3μs							346	ダンパ内蔵
〃 3634	〃	〃	〃	900	500	10A	90W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	1A			〃							346	〃
〃 3635	〃	〃	〃	900	500	15A	100W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	1.4A			〃							346	〃
〃 3636	〃	〃	〃	900	500	7A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	800			〃							346	
〃 3637	〃	〃	〃	900	500	10A	90W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	1A			〃							346	
〃 3638	〃	〃	〃	900	500	15A	100W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	1.4A			〃							346	
〃 3639	〃	〃	〃	1200	800	6A	100W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	800			〃							346	ダンパ内蔵
〃 3640	〃	〃	〃	1200	800	8A	120W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1.2A			〃							346	〃
〃 3641	〃	〃	〃	1200	800	12A	150W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1.6A			〃							346	〃

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3642	三洋	SW	Si.TP	1200	800	6 A	100W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	800			t_{on}<0.5μs, t_f<0.2μs t_{stg}<3μs							346	
〃 3643	〃	〃	〃	1200	800	8 A	120W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1.2A			〃							346	
〃 3644	〃	〃	〃	1200	800	12A	150W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1.6A			〃							346	
〃 3645	〃	RF	Si.EP	180	160	140	500	150	0.1	80	250	5	10	10	−10					150*	2.8	$C_c r_{bb'}$ 15ps	336	
〃 3646	〃	〃	〃	100	100	1 A	500	150	1	80	150	10	100	10	−100					120*	10	$C_c r_{bb'}$ 30ps	336	
〃 3647	〃	〃	〃	100	100	2 A	500	150	1	80	150	10	100	10	−100					120*	17	$C_c r_{bb'}$ 30ps	336	
〃 3648	〃	〃	〃	180	160	700	500	150	0.1	120	200	10	100	10	−50					120*	8	$C_c r_{bb'}$ 30ps	336	
〃 3649	〃	〃	〃	180	160	1.5A	500	150	0.1	120	150	10	100	10	−50					120*	14	$C_c r_{bb'}$ 30ps	336	
〃 3650	〃	〃	〃	30	25	1.2A	500	150	0.1	20	1500	5	500	10	−50					220*	17		336	
〃 3651	〃	〃	〃	120	100	200	500	150	0.1	80	1300	5	10	10	−10					150*	6.5	$C_c r_{bb'}$ 60ps	336	
〃 3652	日立	〃	Si. E	30	20	300	5 W (Tc=25°C)	150	1 mA	25	80	5	50	5	−100					1200*	5	25*	160	
〃 3653																								
〃 3654																								
〃 3655																								
〃 3656																								
〃 3657	東芝	SW	Si. T	850	850	5 A	80W (Tc=25°C)	150	100	800	12	5	2 A			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<4μs							203	
〃 3658	日立	〃	〃	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	500	1200	12	5	1 A			t_r<1.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2μs							102	ダンパ内蔵
〃 3659	〃	〃	〃	1700	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	500	1400	12	5	1 A			t_r<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2μs							102	ダンパ内蔵
〃 3660	日電	PA	Si. E	55	32	24A	290W (Tc=25°C)	200	8 mA	30	60	10	2 A			P_o=105W (f=620MHz, V_{CC}=28V, P_i=16W)					C_{re} 120		395	
〃 3661	三洋	AF	Si.EP	30	25	300	200	150	0.1	20	1500	5	10	10	−10					250*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 170ps	176	
〃 3662	東芝	RF	Si. P	25	20	20	150	125	0.1	10	100	10	2	10	−2					1100*	0.6	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	394B	
〃 3663	日電	RF. LN	Si. E	15	8	5	50	150	0.1	5	100	1	0.25	1	−1	MAG=12.5dB (1 GHz) $\|S_{21e}\|^2$=6.5dB (〃)				4000*	C_{re} 0.4		176	
〃 3664	三洋	SW	Si.TP	800	400	20A	150W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	240	5	20A			t_{on}<4μs, t_f<1.5μs t_{stg}<4μs							346	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 3665	東芝	RF	Si. E	120	120	800	1 W	150	0.1	120	140	5	100	5	−100					120*	12	6*	387	
〃 3666	〃	〃	〃	30	30	1 A	1 W	150	0.1	30	200	2	100	2	−100					150*	13	20	387	
〃 3667	〃	〃	〃	30	30	1.5A	1 W	150	0.1	30	200	2	500	2	−500					120*	12	8*	387	
〃 3668	〃	〃	〃	50	50	2 A	1 W	150	0.1	50	150	2	500	2	−500					100*	30	7*	387	
〃 3669	〃	〃	〃	80	80	2 A	1 W	150	1	80	150	2	500	2	−500					100*	30	7*	387	
〃 3670	〃	〃	〃	30	10	2 A	1 W	150	0.1	30	300	1	500	1	−500					150*	27	6*	387	
〃 3671	〃	〃	〃	50	20	5 A	1 W	150	0.1	40	240	2	500	2	−500					100*	40	16	387	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3672	東芝	RF	Si. E	300	300	100	1 W	150	0.1	300	100	10	20	10	−20					80 *	3	15	387	
〃 3673	〃	〃	〃	40	40	2 A	1 W	150	10	40	1000	1	400	2	−100					220 *	20	10 *	387	
〃 3674	松下	〃	Si. EP	15	10	65	400	150	1	10	120	8	7	8	−20	NF= 2 dB (8 V, 7 mA, 2 GHz)				8000*	0.5	0.16	314	
〃 3675	三洋	SW	Si. TP	1500	900	100	10W (T_c=25°C)	150	10	900	40	5	10			t_{on}< 2 μs, t_f< 2 μs t_{stg}< 9 μs							268	
〃 3676	〃	〃	〃	1500	900	300	20W (T_c=25°C)	150	10	900	40	5	30			〃							268	
〃 3677	東芝	RF	Si. EP	60	60	3 A	25W (T_c=25°C)	150	10	60	2000	5	500	5	−500					170 *	60	2 *	381	
〃 3678	サンケン	SW	Si. TP	900	800	3 A	80W (T_c=25°C)	150	100	800	15	4	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 5 μs							324	
〃 3679	〃	〃	〃	900	800	5 A	100W (T_c=25°C)	150	100	800	15	4	2 A			〃							324	
〃 3680	〃	〃	〃	900	800	7 A	120W (T_c=25°C)	150	100	800	15	4	3 A			〃							324	
〃 3681	三洋	〃	〃	1500	800	6 A	120W (T_c=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.2μs t_{stg}< 3 μs							346	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 3682	〃	〃	〃	1500	800	7 A	120W (T_c=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							346	〃
〃 3683	〃	〃	〃	1500	800	8 A	150W (T_c=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							346	〃
〃 3684	〃	〃	〃	1500	800	10A	150W (T_c=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							346	〃
〃 3685	〃	〃	〃	1500	800	6 A	120W (T_c=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							346	水平偏向用
〃 3686	〃	〃	〃	1500	800	7 A	120W (T_c=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							346	〃
〃 3687	〃	〃	〃	1500	800	8 A	150W (T_c=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							346	〃
〃 3688	〃	〃	〃	1500	800	10A	150W (T_c=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							346	〃
〃 3689	〃	RF	Si. EP	60	50	100	200	125	0.1	40	1500	5	10	10	−10					200 *	1.5	$C_c r_{bb'}$ 125ps	176	
〃 3690	日電	SW	Si. E	100	60	3 A	15W (T_c=25°C)	150	10	100	200	2	600			t_{on}<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							96	
〃 3691	〃	〃	〃	100	60	5 A	25W (T_c=25°C)	150	10	60	200	2	1 A	10	−500	〃				150 *	70		96	
〃 3692	〃	〃	〃	100	60	7 A	30W (T_c=25°C)	150	10	60	200	2	1.5A	10	−1A	〃				150 *	100		96	
〃 3693	〃	〃	〃	100	60	10A	30W (T_c=25°C)	150	10	60	200	2	2 A	10	−1A	〃				140 *	150		96	
〃 3694	〃	〃	〃	100	60	15A	30W (T_c=25°C)	150	10	60	200	2	3 A	10	−1.5A	〃				120 *	180		96	
〃 3695	〃	〃	〃	150	100	3 A	15W (T_c=25°C)	150	10	150	200	2	600			〃							96	
〃 3696	〃	〃	〃	150	100	5 A	20W (T_c=25°C)	150	10	150	200	2	1 A			〃							96	
〃 3697	〃	〃	〃	150	100	7 A	25W (T_c=25°C)	150	10	150	200	2	1.5A			〃							96	
〃 3698	〃	〃	〃	150	100	10A	30W (T_c=25°C)	150	10	150	200	2	2 A			〃							96	
〃 3699	〃	〃	〃	150	100	15A	30W (T_c=25°C)	150	10	150	200	2	3 A			〃							96	
〃 3700	富士通	PA	〃	55	35	6 A	55W (T_c=25°C)	200	1 mA	20	40	5	5 A			P_o=30W (f=860MHz, V_{CC}=28V, P_i=6.5W)					30		396	
〃 3701	〃	〃	〃	55	35	12A	90W (T_c=25°C)	200	2 mA	20	40	5	10A			P_o=50W (f=860MHz, V_{CC}=28V, P_i=13W)					55		396	FJ0850 -28

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3702	富士通	PA	Si. E	55	35	20A	175W (Tc=25°C)	200	3.6mA	20	40	5	18A			P_o=80W (f=860MHz, V_{CC}=28V, P_i=25W)					95		396	FJ0880 -28
〃 3703	新電元	SW	Si. T	230	230	30A	300W (Tc=25°C)	150	100	230	30	2	20A			t_{on}<0.7μs, t_{off}<20μs t_{stg}<1.8μs							266	T30R20
〃 3704	松下	RF	Si. EP	15	10	80	200	150	1	15	150	8	20	8	−20	NF= 1 dB (8 V, 7 mA, 0.8GHz)				6000*	0.7	800	176	
〃 3705	三洋	AF. PA. SW	〃	50	50	1.2A	10W (Tc=25°C)	150	10	40	4000	5	500	5	−500	t_{on}<0.2μs, t_f<0.4μs t_{stg}<2.2μs				180*			296	ダーリントン
★ 〃 3706	サンケン	SW	Si. TMe	230	230	50A	200W (Tc=25°C)	150	100	230	15	0.5	30A			t_{on}<1.2μs, t_{off}<2.5μs t_{stg}<2.3μs							230	
〃 3707	松下	RF	Si. EP	10	7	10	50	150	0.1	10	100	1	1	1	−1	NF=3.5dB (1 V, 1 mA, 800MHz)				4000*	0.4	700	176	
〃 3708	三洋	〃	〃	100	80	500	600	150	0.1	40	150	10	10	10	−10					120*	5	$C_c r_{bb'}$ 35ps	138	2SA1450 とコンプリ
〃 3709	東芝	SW	Si. E	60	50	12A	30W (Tc=25°C)	150	10	60	120	1	1 A			t_{on}<0.6μs, t_f<0.6μs t_{stg}< 3 μs							381	
〃 3710	〃	〃	〃	80	80	12A	30W (Tc=25°C)	150	10	80	120	1	1 A			〃							381	
★ 〃 3711	〃	RF. AF	Si. EP	60	50	100	200	125	0.1	60	400	6	2	6	−2					200*	1.6	50	287	
〃 3712	日電	PA	Si. E	35	16	16A	160W (Tc=25°C)	200	2.4mA	20	60					P_o=50~60~W, G_{pe}=4.5~5.3~dB (f=860MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=18W)							375A	
〃 3713	東芝	RF	〃	60	50	100	150	125	0.1	60	300	6	2	6	−2					200*	1.6	50	176	
〃 3714	新電元	SW	Si. T	500	400	20A	200W (Tc=25°C)	150	100	500	15	2	10A	10	−2A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 2 μs				20*			407	
〃 3715	東芝	〃	Si. TMe	1500	600	4 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	10	5	1 A			t_{on}< 2 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							382	ダンパ内蔵
〃 3716	〃	〃	〃	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	10	5	1 A			〃							382	
〃 3717	〃	RF. Conv.	Si. EP	30	20	50	200	125	0.1	30	120	6	1	6	−1	G_{pe}=21dB, NF= 2 dB (6 V, 1 mA, 100MHz)				750*	1	$C_c r_{bb'}$ 30ps	287	
〃 3718	〃	〃	〃	30	20	50	150	125	0.1	30	120	6	1	6	−1	〃				750*	1	$C_c r_{bb'}$ 30ps	176	
〃 3719	松下	SW	Si. TP	1200	800	5 A	150W (Tc=25°C)	175	100	1000	10	5	2 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3.5μs							102	
〃 3720	〃	〃	〃	1200	800	10A	200W (Tc=25°C)	175	100	1000	10	5	4 A			〃							102	
〃 3721	日立	RF	Si. E	15	10	50	200	150	1	12	120	5	20	5	−20	G_{pe}=12.5dB, NF=1.2dB (5 V, 20mA, 900MHz) (5 mA)				7000*	1	50*	240C	
〃 3722	ローム	〃	Si. EP	120	120	50	200	125	0.5	100	390	6	2	12	−2	NF=0.2dB (6 V, 0.1mA, 100Hz)				140*	3	$C_c r_{bb'}$ 120ps	335	
〃 3723	富士電機	SW	Si. TP	450	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	450	15	5	2 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs							268	
〃 3724	〃	〃	〃	450	400	10A	80W (Tc=25°C)	150	100	450	15	5	4 A			〃							211	
〃 3725	〃	〃	〃	450	400	15A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	15	5	6 A			〃							211	
〃 3726	三菱	RF. AF. PA	Si. E	50	40	2 A	900	150	0.1	40	1200	6	100	10	−20					150*	20		6	
〃 3727	〃	RF. AF. LN	〃	50	40	2 A	1 W (セラミック基板使用)	150	0.1	40	1200	6	100	10	−20					150*	20		336	
〃 3728	〃	〃	〃	20	12	2 A	1 W (セラミック基板使用)	150	0.1	16	350	4	100	2	−10					80*	28		336	
〃 3729	日立	SW	Si. T	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1500	20	5	300			t_{on}<1.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							373	
〃 3730	〃	RF	Si. E	15	10	50	150	150	1	12	120	5	20	5	−20	G_{pe}=11.5dB, NF=1.2dB (5 V, 20mA, 900MHz)(5 V, 5 mA, 900MHz)				7500*	0.9	50*	176	
〃 3731	日電	SW	〃	60	40	200	250	150	0.1	30	200	1	10	20	−10	t_{on}<70ns, t_{off}<250ns t_{stg}<200ns				510*	3		42	2SA1458 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ / f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC3732	日電	SW	Si. E	40	15	200	250	150	0.1	20	90	1	10	10	−10	t_{on}<12ns, t_{stg}<13ns	t_{off}<18ns			750*	1.8		42	2SA1459とコンプリ
〃 3733	〃	RF. SW	〃	80	45	1 A	1 W	150	0.5	45	60~200	10	50	10	−100	t_{on}<40ns, t_{stg}<80ns	t_{off}<110ns			380*	6.7		278	2SA1460とコンプリ
〃 3734	〃	〃	〃	60	40	200	200	150	0.1	30	200	1	10	20	−10	t_{on}<70ns, t_{stg}<200ns	t_{off}<250ns			510*	3		176	2SA1461とコンプリ
〃 3735	〃	SW	〃	40	15	200	200	150	0.1	20	90	1	10	10	−10	t_{on}<12ns, t_{stg}<13ns	t_{off}<18ns			750*	1.8		176	2SA1462とコンプリ
〃 3736	〃	RF. SW	〃	80	45	1 A	2 W (セラミック基板使用)	150	0.5	45	60~200	10	50	10	−100	t_{on}<40ns, t_{stg}<80ns	t_{off}<110ns			380*	6.7		336	2SA1463とコンプリ
〃 3737	松下	SW	Si. TP	1200	800	5 A	125W (T_c=25°C)	150	100	1000	10	5	2 A			t_{on}< 1 μs, t_{stg}<3.5μs	t_f<0.3μs						82	
〃 3738	〃	〃	〃	1200	800	10A	175W (T_c=25°C)	150	100	1000	10	5	4 A			〃							393	
〃 3739	日電	RF. SW	Si. E	60	40	500	200	150	0.1	40	150	1	150	10	−20	t_{on}<35ns, t_{stg}<225ns	t_{off}<275ns			400*	3.5		176	2SA1464とコンプリ
〃 3740	〃	〃	〃	30	25	1 A	400 (セラミック基板使用)	150	0.1	25	200	1	100			t_{on}< 1 μs, t_{stg}< 2 μs	t_f< 1 μs						138	2SA1465とコンプリ
〃 3741	〃	〃	〃	30	25	1 A	250 (セラミック基板使用)	150	0.1	25	200	1	100			〃							42	2SA1466とコンプリ
〃 3742	〃	〃	〃	30	25	1 A	200 (セラミック基板使用)	150	0.1	25	200	1	100			〃							176	2SA1467とコンプリ
〃 3743	松下	〃	Si. TP	900	800	3 A	40W (T_c=25°C)	150	50	900	10	5	800			t_{on}< 1 μs, t_{stg}<4 μs	t_f< 1 μs						364	
〃 3744	日立	RF	Si. E	180	180	100	150	150	0.5	160	200	12	2	12	−10					100*	3	12*	176	
〃 3745	東芝	〃	〃	20	7	30	150	125	1	10	120	5	10	5	−10	NF=2.3dB (5 V, 5 mA, 1 GHz)				6500*	0.7	60*	394A	
〃 3746	三洋	SW	Si. EP	80	60	5 A	20W (T_c=25°C)	150	100	60	150	2	1 A			t_{on}<0.1μs, t_{stg}<1.4μs	t_f<0.2μs						388	
〃 3747	〃	〃	〃	80	60	7 A	25W (T_c=25°C)	150	100	60	150	2	1 A			〃							388	
〃 3748	〃	〃	〃	80	60	12A	30W (T_c=25°C)	150	100	60	150	2	1 A			〃							388	
〃 3749	〃	〃	〃	800	500	3 A	25W (T_c=25°C)	150	10	500	12	5	1.5A			t_{on}<0.5μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs						388	
〃 3750	〃	〃	〃	800	500	5 A	25W (T_c=25°C)	150	10	500	12	5	3 A			〃							388	
〃 3751	〃	〃	〃	1100	800	1.5A	25W (T_c=25°C)	150	10	800	12	5	500			〃							388	
〃 3752	〃	〃	Si. TP	1100	800	3 A	30W (T_c=25°C)	150	10	800	12	5	1 A			〃							388	
〃 3753	〃	〃	〃	1500	800	5 A	60W (T_c=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_{stg}< 3 μs	t_f<0.3μs						397	ダンパ内蔵
〃 3754	〃	〃	〃	1500	800	6 A	60W (T_c=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	ダンパ内蔵
〃 3755	〃	〃	〃	1500	800	5 A	60W (T_c=25°C)	150	10	800	25	5	1 A			〃							397	
〃 3756	〃	〃	〃	1500	800	5 A	60W (T_c=25°C)	150	10	800	25	5	1 A			〃							397	
〃 3757	松下	〃	Si. EP	40	40S	100	200	150	0.1	40	150	1	10	10	−10	t_{on}<30ns, t_{stg}<20ns	t_{off}<40ns			450*	2		176	
〃 3758	日電	〃	Si. T	500	400	10A	70W (T_c=25°C)	150	100	400	10~60	5	1 A	10	−1A	t_{on}<0.3μs, t_{stg}<1.5μs	t_f<0.3μs			30*	120		404	
〃 3759	〃	〃	〃	500	400	15A	75W (T_c=25°C)	150	100	400	35	5	1.5A			t_{on}<0.5μs, t_{stg}<1.5μs	t_f<0.3μs						404	
〃 3760	〃	〃	〃	500	400	10A	65W (T_c=25°C)	150	100	400	35	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_{stg}<2.5μs	t_f<0.7μs						404	
〃 3761	〃	〃	〃	500	400	15A	75W (T_c=25°C)	150	100	400	35	5	2 A			〃							404	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3762	日電	SW	Si. E	150	100	15A	65W (Tc=25°C)	150	10	100	30~120	5	5 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							404	
〃 3763	〃	〃	Si. T	1000	800	3 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	20	5	200			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							404	
〃 3764	〃	〃	〃	1000	800	4 A	65W (Tc=25°C)	150	10	800	20	5	300			〃							404	
〃 3765	〃	〃	〃	1000	800	6 A	70W (Tc=25°C)	150	100	800	20	5	500			〃							404	
〃 3766	〃	〃	〃	1000	800	8 A	75W (Tc=25°C)	150	100	800	20	5	800			〃							404	
★ 〃 3767																								
★ 〃 3768																								
〃 3769	日立	SW	Si. T	1500	600	8 A	50W (Tc=25°C)	150	500	1200	30	5	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}= 5 μs							102	
〃 3770	三洋	Mix. Osc	Si. EP	30	20	30	250	150	1	20	100	10	5	10	−3					1200*	0.7	C_c $r_{bb'}$ 2 ps	176	
〃 3771	〃	〃	〃	30	20	30	250	150	1	20	100	10	5	10	−5					2200*	0.7	C_c $r_{bb'}$ 2 ps	176	
〃 3772	〃	〃	〃	25	16	70	250	150	1	16	100	10	10	10	−10					3000*	0.65	C_c $r_{bb'}$ 2 ps	176	
〃 3773	〃	〃	〃	25	16	50	250	150	1	16	100	10	5	10	−5					3500*	0.6	C_c $r_{bb'}$ 2 ps	176	
〃 3774	〃	RF	〃	20	12	70	250	150	1	12	100	10	20	10	−20					5000*	0.75	C_c $r_{bb'}$ 2 ps	176	
〃 3775	〃	〃	〃	20	12	100	250	150	1	12	100	10	20	10	−20					5000*	0.9	C_c $r_{bb'}$ 2 ps	176	
〃 3776	〃	〃	〃	25	16	70	400	150	1	16	100	10	10	10	−10					3000*	0.7	C_c $r_{bb'}$ 2 ps	138C	
〃 3777	〃	RF. Mix Osc	〃	25	16	50	400	150	1	16	100	10	5	10	−5					3500*	0.7	C_c $r_{bb'}$ 2 ps	138C	
〃 3778	〃	RF	〃	20	12	70	500	150	1	12	100	10	20	10	−20					5000*	0.8	C_c $r_{bb'}$ 2 ps	138C	
〃 3779	〃	〃	〃	20	12	100	600	150	1	12	100	10	20	10	−20					5000*	1	C_c $r_{bb'}$ 2 ps	138C	
〃 3780	〃	〃	〃	80	60	600	1.75W	150	0.1	60	100	10	50	10	−100					800*	5.3	C_c $r_{bb'}$ 5 ps	268	2SA1474 とコンプリ
〃 3781	〃	〃	〃	120	120	400	1.75W	150	0.1	80	100	10	50	10	−50					500*	3	C_c $r_{bb'}$ 5 ps	268	2SA1475 とコンプリ
〃 3782	〃	〃	〃	200	200	200	1.75W	150	0.1	150	150	10	10	30	−50					400*	2.6	C_c $r_{bb'}$ 5 ps	268	2SA1476 とコンプリ
〃 3783	東芝	SW	Si. T	900	800	3 A	100W (Tc=25°C)	150	100	800	20	5	3 A			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<3.5μs							203	
〃 3784	三洋	〃	Si. EP	50	50	1.2A	20W (Tc=25°C)	150	10	40	4000	5	500	5	−500	t_{on}<0.2μs, t_f<0.4μs t_{stg}<2.2μs				180*			398	ダーリントン
〃 3785	〃	〃	〃	50	50	2 A	20W (Tc=25°C)	150	10	40	4000	5	1 A	5	−1A	t_{on}<0.2μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3.5μs				180*			398	ダーリントン
〃 3786	〃	〃	〃	50	50	3 A	20W (Tc=25°C)	150	10	40	4000	5	1.5A	5	−1.5A	t_{on}<0.2μs, t_f<0.7μs t_{stg}<3.5μs				180*			398	ダーリントン
〃 3787	〃	〃	〃	180	160	140	10W (Tc=25°C)	150	0.1	120	200	5	10	10	−10	t_{on}<0.1μs, t_f<0.1μs t_{stg}<1.5μs				150*	3		389	2SA1477 とコンプリ
〃 3788	〃	RF	〃	200	200	100	5 W (Tc=25°C)	150	0.1	150	100	10	10	30	−10					150*	1.7	C_c $r_{bb'}$ 18ps	389	2SA1478 とコンプリ
〃 3789	〃	〃	〃	300	300	100	7 W (Tc=25°C)	150	0.1	200	100	10	10	30	−10					70*	2.6	C_c $r_{bb'}$ 18ps	389	2SA1479 とコンプリ
〃 3790	〃	〃	〃	300	300	100	7 W (Tc=25°C)	150	0.1	200	100	10	10	30	−10					150*	3.1		389	2SA1480 とコンプリ
〃 3791	〃	〃	〃	15	10	80	250	135	1	10	150	8	20	8	−20	G_{pmax}=15dB, NF=1.2dB (8 V, 20mA, 800MHz)				6000*	0.7		337B	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3792	三洋	RF	Si.EP	50	20	500	500	150	0.1	40	600	5	10	10	−10					250*	4	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138	
〃 3793	日立	Osc	Si.E	20	15	50	150	150	1	15	80	10	5	10	−5					2900*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 2 ps	176	
〃 3794	松下	SW	Si.TP	800	500	1.5A	25W (T_c=25°C)	150	100	800	12	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							364	
〃 3795	〃	〃	〃	800	500	5 A	40W (T_c=25°C)	150	100	800	13	5	3 A			〃							364	
〃 3796	〃	〃	〃	800	500	5 A	70W (T_c=25°C)	150	100	800	13	5	3 A			〃							365	
〃 3797	〃	〃	〃	800	500	7 A	100W (T_c=25°C)	150	100	800	12	5	5 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<3.5μs							365	
〃 3798	〃	〃	〃	800	500	5 A	70W (T_c=25°C)	150	100	800	13	5	3 A			〃							82	
〃 3799	〃	〃	〃	800	500	7 A	100W (T_c=25°C)	150	100	800	12	5	5 A			〃							82	
〃 3800	ローム	RF. AF. LN	Si.EP	150	150	50	800	135	0.5	125	220	6	2	12	−2	NF=〜0.2〜3 dB (6 V, 0.1mA, 100Hz)				140*	3	$C_c r_{bb'}$ 120ps	334	2SA1482とコンプリ
〃 3801	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	30	25	30	250	125	0.1	25	100	10	4	10	−10					1100*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	138C	
〃 3802	〃	〃	〃	30	25	30	200	125	0.1	25	100	10	4	10	−10					1100*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	176	
〃 3803	東芝	RF	Si.E	60	45	200	500	150	0.1	45	100	1	10	10	−10					200*	3	60*	336	
〃 3804	三菱	PA	Si.EP	35	17	12A	100W (T_c=25°C)	175	5 mA	15	40	10	1 A			P_o=45W (f=850MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=20W)							401	
〃 3805	東芝	RF. PA	Si.T	300	300	100	10W (T_c=25°C)	150	1	240	80	10	20	20	−20					95*	3	10	344	
〃 3806	日立	RF	Si.E	15	12	50	150	150	10	15	80	5	20	5	−20	NF=2.1dB (5 V, 5 mA, 900MHz)				4500*	1.1	53*	50C	
〃 3807	三洋	〃	Si.EP	30	25	2 A	20W (T_c=25°C)	150	0.1	20	1500	5	500	10	−50					260*	27	$C_c r_{bb'}$ 170ps	398	
〃 3808	〃	RF	〃	80	60	2 A	20W (T_c=25°C)	150	1	50	1500	5	500	10	−50					170*	24	$C_c r_{bb'}$ 265ps	398	
〃 3809	日電	Diff	Si.E	20	12	100	150/unit	200	1	10	120	10	20	10	−20	h_{FE1}/h_{FE2}=0.6〜1.0				7000*	C_{re} 0.75		307A	2素子複合
〃 3810	〃	〃	〃	20	10	65	150/unit	200	0.1	10	100	8	20	8	−20	〃				8000*	C_{re} 0.5		307A	2素子複合
〃 3811	松下	SW	Si.EP	40	40	100	400	150	0.1	40	120	1	10	10	−10	t_{on}=17ns, t_{off}=17ns t_{stg}=10ns				450*	2		138D	
〃 3812	日電	PA	Si.E	55	32	48A	580W (T_c=25°C)	200	10mA	30	60	10	8 A	28	−500	P_o=200W, AB級PP (f=230MHz, V_{CC}=28V, I_C=0.5A×2)				350*	320		395	2素子複合
〃 3813	東芝	〃	Si.TMe	300	100	7 A	150W (T_c=25°C)	150	10	250	100	5	1 A	5	−500					10*	100	10	203	
〃 3814	日電	〃	Si.E	20	12	500	8.3W (T_c=25°C)	200	100	15	60	7	100			P_o= 1 W (f=940MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=0.1W)					C_{re} < 5		399	
〃 3815	〃	〃	〃	20	12	1.5A	17.5W (T_c=25°C)	200	250	15	60	7	200			P_o=3.2W (f=940MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=0.7W)					C_{re} <20		399	
〃 3816	〃	〃	〃	20	12	3 A	35W (T_c=25°C)	200	500	15	60	7	400			P_o=6.3W (f=940MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=2.3W)					C_{re} <40		399	
〃 3817	〃	〃	〃	35	18	500	8.3W (T_c=25°C)	200	100	20	60	10	100			P_o= 1 W (f=1.55GHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.16W)					C_{re} < 5		375B	
〃 3818	〃	〃	〃	35	18	2 A	19.4W (T_c=25°C)	200	500	20	60	10	400			P_o= 4 W (f=1.55GHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.8W)					C_{re} <15		375B	
〃 3819	〃	〃	〃	35	18	4 A	46W (T_c=25°C)	200	1 mA	20	60	10	800			P_o=10W (f=1.55GHz, V_{CC}=13.5V, P_i=3.2W)					C_{re} <30		375B	
〃 3820	三洋	RF	Si.EP	60	50	100	300	150	0.1	40	1500	5	10	10	−10					200*	2	$C_c r_{bb'}$ 130ps	92	
〃 3821	富士電機	SW	Si.TP	450	400	5 A	40W (T_c=25°C)	150	1 mA	450	20	5	2 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							402	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3822	富士電機	SW	Si.TP	450	400	5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	450	15	5	2 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2.5μs							402	
〃 3823	日立	〃	Si.E	120	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	0.5	100	120	1	2.5A			〃							268	
〃 3824	松下	〃	Si.TP	900	800	1 A	15W (Tc=25°C)	150	50	900	10	5	500			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							392	
〃 3825	〃	〃	Si.TMe	500	400	2 A	15W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	1 A			〃							392	
〃 3826	日電	〃	Si.E	200	100	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	100	5	3 A	5	−1A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.8μs t_{stg}< 2 μs				30 *	200		268	
〃 3827	〃	Osc	〃	30	15	20	200	125	0.1	15	100	10	5	10	− 5					1300*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	176	
〃 3828	東芝	RF	Si.P	25	20	20	150	125	0.1	10	100	10	2	10	− 2	G_{pb}=17dB (V_{CC}=12V, V_{AGC}= 3 V, f=800MHz)				1100*	0.6	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	394B	フォワードAGC
〃 3829	松下	RF.LN	Si.EP	15	10	80	200	150	1	10	150	8	20	8	−20	G_{pe}=15dB, NF=1.4dB (800MHz)				6000*	0.7	450	176	
〃 3830	サンケン	SW	Si.TP	600	500	6 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	15	4	2 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}<4.5μs							298	
〃 3831	〃	〃	〃	600	500	10A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	15	4	5 A			〃							324	
〃 3832	〃	〃	〃	500	400	7 A	50W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							298	
〃 3833	〃	〃	〃	500	400	12A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	7 A			〃							324	
〃 3834	〃	〃	〃	200	120	7 A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	120	4	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							298	
〃 3835	〃	〃	〃	200	120	7 A	70W (Tc=25°C)	150	100	200	120	4	3 A			〃							324	
〃 3836	日立	RF.SW	Si.E	60	50	300	300	150	1	50	800~2000	6	100										378	
〃 3837	ローム	RF.Conv.Mix Osc.PA	Si.EP	30	18	50	150	125	0.5	10	85	10	10	10	−10	NF=4.5dB (12V, 2 mA, 200MHz)				1500*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	176	
〃 3838	〃	〃	〃	20	11	50	150	125	0.5	10	85	10	5	10	−10	NF=3.5dB (6 V, 2 mA, 500MHz)				3200*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	176	
〃 3839	〃	〃	〃	30	20	50	150	125	0.5	15	85	10	5	10	−10	NF= 3 dB (10V, 2 mA, 200MHz)				2000*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 3.5ps	176	
〃 3840	日電	SW	Si.T	600	600	1 A	15W (Tc=25°C)	150	10	600	55	5	100	10	−50	t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs				30 *	14		225	
〃 3841	〃	Osc	Si.E	25	12	30	200	150	0.1	10	100	10	5	10	− 5					4000*	0.85	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	176	
〃 3842	富士通	SW	Si.TP	600	400	10A	70W (Tc=25°C)	150	100	500	17	5	5 A	10	−1A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.12μs				32 *	100		409	
〃 3843	〃	〃	〃	600	450	10A	75W (Tc=25°C)	150	100	500	14	5	6 A	10	−2A	t_{on}<0.3μs, t_f<0.2μs t_{stg}<1.5μs				28 *	230		409	
〃 3844	〃	〃	〃	600	450	15A	75W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	10A	10	−2A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.5μs				30 *	240		409	
〃 3845	〃	〃	〃	1200	800	3 A	75W (Tc=25°C)	150	100	1000	15	5	1 A	10	−200	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3.5μs				15 *	60		409	
〃 3846	〃	〃	〃	1200	800	6 A	80W (Tc=25°C)	150	100	1000	15	5	2 A	10	−500	〃				15 *	120		409	
〃 3847	〃	〃	〃	1200	800	10A	85W (Tc=25°C)	150	100	1000	15	5	4 A	10	−100	〃				28 *	220		409	
〃 3848	ローム	RF	Si.EP	25	20	200	200	125	0.1	15	80	0.5	1	10	−10					500 *	3	$C_c r_{bb'}$ 20ps	176	
〃 3849	日電	Diff	Si.E	20	10	80	500/unit	200	0.1	10	100	5	30	6	−30	h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0				7000*	1		308	2素子複合
〃 3850	松下	SW	Si.TP	500	400	20A	125W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	10A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							365	
〃 3851	サンケン	PA	〃	80	60	4 A	25W (Tc=25°C)	150	100	80	100	4	1 A	12	−200					15 *	60	10	400	2SA1488とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC3852	サンケン	PA	Si.TP	80	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	10	80	1000	4	500	12	−200					15 *	50	30	400	
〃 3853	〃	〃	〃	120	80	6 A	60W (Tc=25°C)	150	100	120	>50	4	2 A	12	−500					20 *			324	2SA1489 とコンプリ
〃 3854	〃	〃	〃	160	120	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	160	>50	4	3 A	12	−500					20 *			324	2SA1490 とコンプリ
〃 3855	〃	〃	〃	200	140	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	140	>50	4	3 A	12	−500					20 *			324	2SA1491 とコンプリ
〃 3856	〃	〃	〃	200	180	15A	130W (Tc=25°C)	150	100	200	>50	4	3 A	12	−500					20 *			324	2SA1492 とコンプリ
〃 3857	〃	〃	〃	200	200	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	200	>30	4	5 A	12	−500					20 *			256	2SA1493 とコンプリ
〃 3858	〃	〃	〃	200	200	17A	200W (Tc=25°C)	150	100	200	>30	4	8 A	12	−1A					20 *			256	2SA1494 とコンプリ
〃 3859	三洋	SW	Si.EP	50	50	100	200	150	0.1	40	300	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10kΩ)						250 *	3.5		176	2SA1496 とコンプリ
〃 3860	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	300	5	10	〃						250 *	3.7		92	2SA1497 とコンプリ
〃 3861	松下	RF	〃	10	7	10	70	150	0.1	10	100	1	1	1	−1					4000*	0.4	700	138C	
〃 3862	東芝	Conv	〃	30	15	50	150	125	0.1	30	100	10	5	10	−2	G_{ce}=17dB (f=800MHz)				2400*	C_{re} 0.6	$C_c r_{bb'}$ 14ps	176A	
〃 3863	三洋	SW	〃	50	50	100	200	150	0.1	40	250	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=0.22±0.022)						250 *	3.5		176	2SA1502 とコンプリ
〃 3864	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	250	5	10	〃						250 *	3.7		92	2SA1503 とコンプリ
〃 3865	富士電機	〃	Si.TP	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	500	20	5	2 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.15μs t_{stg}<1.5μs							402	
〃 3866	〃	〃	〃	900	800	3 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	12	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.8μs t_{stg}< 4 μs							402	
〃 3867	日立	Conv	Si.E	20	11	50	150	125	0.5	15	90	10	10	10	−20	G_{ce}=14dB (f=900MHz)				3800*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176A	
〃 3868	松下	SW	Si.TP	500	400	2 A	25W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	1 A			t_{on}<0.7μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 2 μs							364	
〃 3869	〃	〃	〃	500	400	5 A	35W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	2 A			〃							364	
〃 3870	〃	〃	〃	500	400	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	3 A			〃							364	
〃 3871	〃	〃	〃	500	400	10A	45W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	5 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							364	
〃 3872	〃	〃	〃	500	400	10A	70W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	5 A			〃							82	
〃 3873	〃	〃	〃	500	400	12A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	7 A			〃							82	
〃 3874	〃	〃	〃	500	400	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	10A			〃							393	
〃 3875	韓国電子	RF. AF	Si.EP	60	50	150	150	125	0.1	60	240	6	2	10	−1	NF= 1 dB (6 V, 0.1mA, 1 kHz)				130 *	2	50	176C	
〃 3876	〃	〃	〃	35	30	500	150	125	0.1	35	150	1	100	6	−20					300 *	7	$C_c r_{bb'}$ 40ps	176C	
〃 3877	〃	RF. AF. LN	〃	120	120	100	150	125	0.1	120	415	6	2	6	−1	NF=0.2dB (6 V, 0.1mA, 1 kHz)				100 *	4	13	176C	
〃 3878	〃	RF. Conv.	〃	35	30	100	150	125	0.1	20	85	12	2	10	−2	NF= 2 dB (10V, 1 mA, 1 MHz)				120 *	2.2	$C_c r_{bb'}$ 30ps	176C	
〃 3879	〃	〃	〃	35	30	50	150	125	0.1	35	110	12	2	10	−1	G_{pe}=29dB (6 V, 1 mA, 10.7MHz)				175 *	1.2	$C_c r_{bb'}$ 25ps	176C	
〃 3880	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	40	30	20	100	125	0.5	40	70	6	1	6	−1	G_{pe}=18dB, NF=2.5dB (6 V, 1 mA, 100MHz)				550 *	0.7	$C_c r_{bb'}$ 10ps	176C	
〃 3881	〃	RF	〃	30	25	50	150	125	0.1	30	70	12.5	12.5	10	−10					600 *	1.5	$C_c r_{bb'}$ 11ps	176C	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3882																								
〃 3883	日立	SW	Si. T	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	500	1200	12	5	1 A			t_{on}<1.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 5 μs							373	ダンパ内蔵
〃 3884	東芝	〃	Si. TP	1400	600	6 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	1 A	10	−100	t_{on}< 2 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 4 μs				8 *	150		382	
〃 3885	〃	〃	〃	1400	600	7 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	1 A	10	−100	〃				8 *	150		382	
〃 3886	〃	〃	〃	1400	600	8 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	1 A	10	−100	〃				8 *	150		382	
〃 3887	〃	〃	〃	1400	600	6 A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	1 A	10	−100	〃				8 *	150		380	
〃 3888	〃	〃	〃	1400	600	7 A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	1 A	10	−100	〃				8 *	150		380	
〃 3889	〃	〃	〃	1400	600	8 A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	1 A	10	−100	〃				8 *	150		380	
〃 3890	サンケン	〃	〃	500	400	7 A	30W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							400	
〃 3891	東芝	〃	〃	1400	600	6 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A			t_{on}< 2 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 4 μs							382	ダンパ内蔵
〃 3892	〃	〃	〃	1400	600	7 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A			〃							382	〃
〃 3893	〃	〃	〃	1400	600	8 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A			〃							382	〃
〃 3894	三洋	〃	〃	1500	800	6 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.2μs t_{stg}< 3 μs							397	水平偏向用
〃 3895	〃	〃	〃	1500	800	7 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 3896	〃	〃	〃	1500	800	8 A	70W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 3897	〃	〃	〃	1500	800	10A	70W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 3898	〃	〃	Si. EP	50	50	100	200	150	0.1	40	250	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=47±14kΩ)						250 *	3.7		176	2SA1508 とコンプリ
〃 3899	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	250	5	10	〃						250 *	3.7		92	2SA1509 とコンプリ
〃 3900	〃	〃	〃	50	50	100	200	150	0.1	40	250	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7±1.4kΩ)						250 *	3.7		176	2SA1510 とコンプリ
〃 3901	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	250	5	10	〃									92	2SA1511 とコンプリ
〃 3902	〃	〃	〃	180	160	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	1	120	250	5	100	10	−50	t_r<0.04μs, t_f<0.08μs t_{stg}<1.2μs				120 *	14		389	2SA1507 とコンプリ
〃 3903	松下	RF	〃	15	10	65	150	125	1	10	120	8	20	8	−20	NF= 2 dB (8 V, 7 mA, 1.5GHz)				9000*	0.6	10	337B	
〃 3904	〃	〃	〃	15	10	65	150	125	1	10	120	8	20	8	−20	NF=1.8dB (8 V, 7 mA, 1.5GHz)				9000*	0.6	11	176	
〃 3905	日電	SW	Si. E	100	60	15A	60W (Tc=25°C)	150	10	60	200	2	3 A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							404	
〃 3906	ローム	RF. AF	Si. EP	120	120	50	200	125	0.5	100	390	6	2	6	−1		10.8k	0.54	4	140 *	3	$C_c r_{bb'}$ 120ps	335	
〃 3907	東芝	PA	Si. T	180	180	12A	130W (Tc=25°C)	150	5	180	100	5	1 A	5	−1A					30 *	270	10	203	2SA1516 とコンプリ
〃 3908	三菱	〃	Si. EP	50	20	25A	250W (Tc=25°C)	175	5 mA	15	50	10	1 A			P_o=120W (V_{CC}=12.5V, f=30MHz, P_i= 7 W)							303	
〃 3909	サンケン	SW	Si. TP	900	800	5 A	100W (Tc=25°C)	150	100	800	15	4	1.5A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 4 μs							324	
〃 3910	松下	〃	Si. TMe	900	500	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	900	16	5	8 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							393	
〃 3911																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC3912	三洋	SW	Si.EP	50	50	500	200	150	0.1	40	200	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10±3kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						250*	3.7		176	2SA1518とコンプリ
〃 3913	〃	〃	〃	50	50	500	200	150	0.1	40	200	5	20	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						250*	3.7		176	2SA1519とコンプリ
〃 3914	〃	〃	〃	50	50	500	200	150	0.1	40	200	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=0.22±0.022)						250*	3.7		176	2SA1520とコンプリ
〃 3915	〃	〃	〃	50	50	500	200	150	0.1	40	200	5	50	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						250*	3.7		176	2SA1521とコンプリ
〃 3916	〃	〃	〃	50	50	500	300	150	0.1	40	200	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10k±0.1kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						250*	3.7		92	2SA1522とコンプリ
〃 3917	〃	〃	〃	50	50	500	300	150	0.1	40	200	5	20	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						250*	3.7		92	2SA1523とコンプリ
〃 3918	〃	〃	〃	50	50	500	300	150	0.1	40	200	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=0.22±0.022)						250*	3.7		92	2SA1524とコンプリ
〃 3919	〃	〃	〃	50	50	500	300	150	0.1	40	200	5	50	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						250*	3.7		92	2SA1525とコンプリ
〃 3920	〃	〃	〃	50	50	500	600	150	0.1	40	200	5	50	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10k±3kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						250*	3.7		138	2SA1526とコンプリ
〃 3921	〃	〃	〃	50	50	500	600	150	0.1	40	200	5	20	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)									138	2SA1527とコンプリ
〃 3922	〃	〃	〃	50	50	500	600	150	0.1	40	200	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=0.22±0.022)						250*	3.7		138	2SA1528とコンプリ
〃 3923	〃	〃	〃	50	50	500	600	150	0.1	40	200	5	50	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)						250*	3.7		138	2SA1529とコンプリ
〃 3924	日立	〃	Si.T	900	800	3A	30W (Tc=25°C)	150	10	750	20	5	300			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<3μs							391	
〃 3925	三洋	Diff	Si.EP	20	12	100	250/unit	150	1	12	100	10	20	10	−20	h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0				5000*	0.9	$C_{c\,bb'}$ 5ps	355	2素子複合
〃 3926	東芝	RF	〃	20	12	30	150	125	0.1	10	120	10	5	10	−10					4000*	1.05	$C_{c\,bb'}$ 4.5ps	176	
〃 3927	サンケン	SW	Si.TP	900	550	10A	120W (Tc=25°C)	150	100	800	15	4	5A			t_{on}<1μs, t_f<0.5μs t_{stg}<5μs							324	
〃 3928	三菱	RF.AF	Si.E	50	50	100	150	125	0.5	50	300	6	1	6	−10					200*	2.5	$C_{c\,bb'}$ 300ps	176	
〃 3929	松下	RF	Si.EP	35	35	50	150	150	0.1	10	350	5	2	10	−10					250*	3.5	170	412	2SA1531とコンプリ ○
〃 3930	〃	〃	〃	30	20	30	150	150	0.1	10	110	10	1	10	−1					250*	1.2	225	412	2SA1532とコンプリ
〃 3931	〃	〃	〃	30	20	15	150	150	0.1	10	250	6	1	6	−1					650*	0.8	400	412	
〃 3932	〃	〃	〃	30	20	50	150	150	0.1	10	120	10	2	10	−15					1200*	1.2	680	412	
〃 3933	〃	〃	〃	30	20	20	150	150	1	25	100	10	3	10	−3					1100*	0.7	350	412	
〃 3934	〃	〃	〃	15	12	30	150	150	0.1	10	100	10	10	10	−10	NF=1.3dB (10V, 5mA, 800MHz)				4500*	0.8	450	412	
〃 3935	〃	〃	〃	15	10	50	150	150	1	10	200	4	5	4	−5					1900*	1.4	$C_{c\,bb'}$ 11ps	412	
〃 3936	〃	〃	〃	30	20	30	150	150	1	10	120	10	1	10	−1					230*	1.1	200	412	
〃 3937	〃	〃	〃	15	10	80	150	150	1	15	150	8	20	8	−20	NF=1dB (8V, 7mA, 800MHz)				6000*	0.7	900	412	
〃 3938	〃	SW	〃	40	40S	100	150	150	0.1	40	160	1	10			t_{on}<25ns, t_{off}<25ns t_{stg}<20ns				450*	2		412	
〃 3939	〃	RF	〃	80	80	500	1W	150	0.1	20	180	10	150	10	−50					120*	11	7	413	2SA1533とコンプリ
〃 3940	〃	〃	〃	30	25	1A	1W	150	0.1	20	180	10	500	10	−50					200*	11	6	413	2SA1534とコンプリ ○
〃 3941	〃	〃	Si.TP	300	300	70	1W	150	2	100	130	10	5	10	−10					80*	4	15	413	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC3942	松下	PA	Si.TP	300	300	100	40W (Tc=25°C)	150	10	250	150	50	5	10	−20					140*	2.7	13	364	
〃 3943	〃	〃	Si.EP	110	50	150	40W (Tc=25°C)	150	100	100	100	5	100	30	−20					350*	3.5	55	364	
〃 3944	〃	〃	〃	150	150	1 A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	160	10	150	10	−10					300*	20	5	364	2SA1535 とコンプリ ○
〃 3945	〃	〃	Si.TP	300	300	100	40W (Tc=25°C)	150	100	250	150	50	5	30	−20					100*	4	10	364	
〃 3946	〃	〃	〃	350	300	200	40W (Tc=25°C)	150	2	200	150	10	10	30	−10					80*	4	28	364	
〃 3947	富士通	SW	Si.T	850	500	5 A	70W (Tc=25°C)	150	100	800	15	5	2.5A	5	−2.5A	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 3 μs				20*	70		409	
〃 3948	〃	〃	〃	850	500	10A	75W (Tc=25°C)	150	100	800	15	5	5 A	5	−5A	〃				20*	130		409	
〃 3949	〃	〃	〃	850	500	15A	80W (Tc=25°C)	150	100	800	15	5	10A	5	−10A	〃				20*	260		409	
〃 3950	三洋	RF	Si.EP	30	20	500	5 W (Tc=25°C)	150	100	20	120	5	50	5	−100					2000*	6	$C_c r_{bb'}$ 3 ps	389	
〃 3951	〃	〃	〃	80	70	300	8 W (Tc=25°C)	150	100	70	120	10	50	10	−100					600*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	389	2SA1536 とコンプリ
〃 3952	〃	〃	〃	80	70	500	10W (Tc=25°C)	150	100	70	120	10	50	10	−100					700*	3.6	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	389	2SA1537 とコンプリ
〃 3953	〃	〃	〃	120	120	200	8 W (Tc=25°C)	150	100	120	120	10	10	10	−50					400*	2.1	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	389	2SA1538 とコンプリ
〃 3954	〃	〃	〃	120	120	300	8 W (Tc=25°C)	150	100	120	120	10	50	10	−50					400*	3.1	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	389	2SA1539 とコンプリ
〃 3955	〃	〃	〃	200	200	100	7 W (Tc=25°C)	150	100	200	120	10	10	30	−30					300*	1.9	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	389	2SA1540 とコンプリ
〃 3956	〃	〃	〃	200	200	200	7 W (Tc=25°C)	150	100	200	120	10	10	30	−50					300*	2.7	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	389	2SA1541 とコンプリ
〃 3957	日立	〃	〃	40	30	300	150	150	0.1	30	10000	5	10	5	−10					100*	3.5	220	408C	ダーリントン
〃 3958	ユニゾン	SW	〃	150	60	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	60	70	5	3 A			t_{on}<0.6μs, t_f<0.6μs t_{stg}<2.5μs							268	
〃 3959	〃	〃	〃	150	80	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	80	70	5	3 A			〃							268	
〃 3960	〃	〃	〃	150	100	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	70	5	2 A			〃							268	
〃 3961	〃	〃	Si.TP	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	10	400	30	5	500			t_{on}< 1 μs, t_f<0.8μs t_{stg}<2.5μs							268	
〃 3962	〃	〃	〃	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	10	400	30	5	500			t_{on}<0.5μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs							268	
〃 3963	東芝	PA	Si.T	200	160	200	1.5W	150	0.1	200	200	10	5～50	10	−50					100*	7	50	384	
〃 3964	〃	SW	Si.E	40	40	2 A	1.5W	150	10	40	1000	1	400	2	−100	t_{on}< 3 μs, t_f<3.5μs t_{stg}<10μs				220*	20	10	384	
〃 3965	松下	RF	Si.TP	300	300	100	1 W	150	1	200	150	50	5	30	−20					140*	2.4	17	413	
〃 3966	〃	〃	Si.EP	30	20	20	200	135	1	25	100	10	3	10	− 3	G_P=17dB, NF=2.8dB (900MHz)				1300*	0.7	380	337A	
〃 3967	〃	〃	〃	30	20	20	150	150	1	25	100	10	3	10	− 3	〃				1300*	0.6	370	176	
〃 3968	ローム	SW	Si.TP	400	400	2 A	20W (Tc=25°C)	150	10	400	25	5	100	10	−500	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs				10*	30		268	
〃 3969	〃	〃	〃	400	400	2 A	20W (Tc=25°C)	150	10	400	25	5	100	10	−500	〃				10*	30		405	
〃 3970	松下	〃	〃	800	500	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	100	800	10	5	1 A			t_{on}<0.7μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 2 μs							364	
〃 3971	〃	〃	〃	800	500	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	800	10	5	2 A			〃							364	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC3972	松下	SW	Si.TP	800	500	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	800	10	5	3 A			t_{on}<0.7μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.5μs							364	
〃 3973	〃	〃	〃	800	500	7 A	45W (Tc=25°C)	150	100	800	10	5	5 A			〃							364	
〃 3974	〃	〃	〃	800	500	7 A	80W (Tc=25°C)	150	100	800	10	5	5 A			〃							82	
〃 3975	〃	〃	〃	800	500	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	800	10	5	7 A			〃							82	
〃 3976	〃	〃	〃	800	500	12A	150W (Tc=25°C)	150	100	800	10	5	10A			〃							393	
〃 3977	〃	〃	〃	1000	800	1 A	30W (Tc=25°C)	150	50	1000	5	5	500			〃							364	
〃 3978	〃	〃	〃	1000	800	2 A	35W (Tc=25°C)	150	50	1000	10	5	1 A			t_{on}<0.7μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 3 μs							364	
〃 3979	〃	〃	〃	1000	800	3 A	40W (Tc=25°C)	150	50	1000	8	5	1.5A			t_{on}<0.7μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3.5μs							364	
〃 3980	〃	〃	〃	1000	800	4 A	70W (Tc=25°C)	150	50	1000	10	5	2 A			t_{on}<0.7μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.5μs							82	
〃 3981	〃	〃	〃	1000	800	5 A	80W (Tc=25°C)	150	50	1000	10	5	3 A			〃							82	
〃 3982	〃	〃	〃	1000	800	10A	150W (Tc=25°C)	150	50	1000	10	5	4 A			t_{on}<0.7μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 3 μs							393	
〃 3983	ローム	RF. AF	Si.EP	60	50	150	300	150	0.5	30	220	6	1	6	−1		13k	0.049	9.6	180*	2	$C_c r_{bb'}$ 120ps	138	2SA1542とコンプリ
〃 3984	〃	〃	〃	60	50	150	300	150	0.5	30	220	6	1	6	−1		13k	0.049	9.6	180*	2	$C_c r_{bb'}$ 120ps	235	
〃 3985	三洋	SW	〃	50	50	1.2A	15W (Tc=25°C)	150	10	40	4000	5	500	5	−500	t_{on}<0.2μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3.5μs				180*			388	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 3986	〃	〃	〃	50	50	2 A	15W (Tc=25°C)	150	10	40	4000	5	1 A	5	−1A	〃				180*			388	〃
〃 3987	〃	〃	〃	50	50	3 A	20W (Tc=25°C)	150	10	40	4000	5	1.5A	5	−1.5A	〃				180*			388	
〃 3988	〃	〃	Si.TP	800	500	25A	150W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	2.4A	10	−2.4A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.2μs t_{stg}< 3 μs				18*	260		346	
〃 3989	〃	〃	〃	800	500	25A	200W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	2.4A	10	−2.4A	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 3 μs				18*	260		414	
〃 3990	〃	〃	〃	800	500	35A	250W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	3.2A	10	−3.2A	〃				18*	400		414	
〃 3991	〃	〃	〃	800	500	50A	300W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	4.8A			〃							414	
〃 3992	〃	〃	〃	1100	800	12A	200W (Tc=25°C)	150	10	800	20	5	800	10	−800	〃				15*	215		414	
〃 3993	〃	〃	〃	1100	800	16A	250W (Tc=25°C)	150	10	800	20	5	1.2A	10	−1.2A	〃				15*	320		414	
〃 3994	〃	〃	〃	1100	800	25A	300W (Tc=25°C)	150	10	800	20	5	1.6A			〃							414	
〃 3995	〃	〃	〃	1500	800	12A	180W (Tc=25°C)	150	10	800	20	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.2μs t_{stg}< 3 μs							414	水平偏向用
〃 3996	〃	〃	〃	1500	800	15A	180W (Tc=25°C)	150	10	800	10	5	1 A			〃							414	〃
〃 3997	〃	〃	〃	1500	800	20A	250W (Tc=25°C)	150	10	800	10	5	1 A			〃							414	〃
〃 3998	〃	〃	〃	1500	800	25A	250W (Tc=25°C)	150	10	800	10	5	1 A			〃							414	〃
〃 3999	日電	RF	Si.E	300	250	100	750	150	0.1	200	200	10	10	30	−30					300*	2.8	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	138	2SA1544とコンプリ
〃 4000	〃	〃	〃	300	250	100	1 W	150	0.1	200	200	10	10	30	−30					300*	2.8	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	278	2SA1545とコンプリ
〃 4001	〃	〃	〃	300	250	100	1.3W	150	0.1	200	200	10	10	30	−30					300*	2.8	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	225	2SA1546とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC4002	三洋	RF	Si.EP	400	400	200	500	150	1	300	50	10	10	30	−10					40 *	4	$C_r r_{bb'}$ 30ps	138	
〃 4003	〃	〃	〃	400	400	200	1 W	150	1	300	50	10	10	30	−10					40 *	4	$C_r r_{bb'}$ 30ps	411	
〃 4004	松下	SW	Si.TP	900	800	1 A	30W (Tc=25°C)	150	50	900	5	5	500			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							364	
〃 4005	三洋	〃	Si.EP	50±8	50±8	2 A	15W (Tc=25°C)	150	10	30	4000	5	1 A	5	−1A	t_{on}<0.2μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3.5μs				180 *			388	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 4006	〃	〃	〃	50±8	50±8	3 A	20W (Tc=25°C)	150	10	30	4000	5	1.5A	5	−1.5A	t_{on}<0.2μs, t_f<0.7μs t_{stg}< 3 μs				180 *			388	〃
〃 4007	ローム	PA	Si.TP	100	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	250	4	1 A	12	−200					10 *	60	10	268	
〃 4008	〃	〃	〃	100	80	4 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	250	4	1 A	12	−200					10 *	60	10	405	
〃 4009	〃	RF.AF	Si.EP	40	32	300	300	125	0.1	30	100000	3	100	5	−10					200 *	2.5	$C_r r_{bb'}$ 100ps	235	ダーリントン
〃 4010	〃	〃	〃	50	40	100	300	125	0.5	30	330	6	1	12	−2					180 *	2.5	$C_r r_{bb'}$ 120ps	415	
〃 4011	〃	RF	〃	40	25	50	250	125	0.5	24	120	6	1	6	−1					300 *	1.6	$C_r r_{bb'}$ 20ps	415	
〃 4012	〃	〃	〃	40	32	100	250	125	0.5	24	82	6	2	12	−2					230 *	1.8	$C_r r_{bb'}$ 10ps	415	
〃 4013	〃	〃	〃	25	20	20	150	125	0.5	20	82	6	1	6	−1					500 *	1.4	$C_r r_{bb'}$ 16ps	415	
〃 4014	〃	〃	〃	30	19	50	300	125	0.5	20	120	10	5	5	−10					1100*	1.2	$C_r r_{bb'}$ 10ps	415	
〃 4015	〃	〃	〃	300	300	100	1 W	135	0.5	200	82	10	10	30	−10					100 *	3	$C_r r_{bb'}$ 100ps	415	
〃 4016	〃	RF.AF.PA	〃	40	32	500	400	125	1	20	180	3	100	5	−20					250 *	6.5	$C_r r_{bb'}$ 60ps	415	
〃 4017	〃	RF.Conv.Mix Osc. PA	〃	40	32	300	300	125	1	24	10000	5	100	5	−10					250 *	5	$C_r r_{bb'}$ 100ps	415	
〃 4018	〃	RF.AF	〃	50	40	100	250	125	0.5	24	180	6	2	6	−2					230 *	1.8	$C_r r_{bb'}$ 22ps	176	
〃 4019	三菱	PA	Si.T	300	220	100	10W (Tc=25°C)	150	1	150	100	10	25	10	−10					90 *	3.5	$C_r r_{bb'}$ 45ps	416	
〃 4020	サンケン	SW	Si.TP	900	800	3 A	50W (Tc=25°C)	150	100	800	15	4	700			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 5 μs							298	
〃 4021	〃	〃	〃	1500	800	3 A	100W (Tc=25°C)	150	100	1200	8	4	1.5A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.3μs t_{stg}<4.5μs							324	
〃 4022	〃	〃	〃	1500	800	6 A	120W (Tc=25°C)	150	100	1200	8	4	3 A			〃							324	
〃 4023	〃	〃	〃	1500	800	10A	130W (Tc=25°C)	150	100	1200	8	4	5 A			〃							324	
〃 4024	〃	〃	〃	100	50	12A	50W (Tc=25°C)	150	10	100	600	4	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							400	
〃 4025																								
〃 4026	松下	SW	Si.TP	500	400	5 A	35W (Tc=25°C)	150	100	500	15	5	2 A			t_{on}<0.7μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 2 μs							364	
〃 4027	三洋	RF	Si.EP	180	160	1.5A	15W (Tc=25°C)	150	1	120	250	5	100	10	−50					120 *	14	$C_r r_{bb'}$ 30ps	411	2SA1552とコンプリ
〃 4028	東芝	SW	Si.T	1400	800	10A	100W (Tc=25°C)	150	10	1200	15	5	3 A			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 4 μs							203	
〃 4029	〃	PA	〃	230	230	15A	150W (Tc=25°C)	150	5	230	100	5	1 A	5	−1A					30 *	270	10	152	
〃 4030	三洋	AF.PA	Si.TP	1700	900	50	1.2W	150	1	900	50	5	2	10	−2	t_{on}< 5 μs, t_f< 5 μs t_{stg}<10μs				6 *	2		418	
〃 4031	〃	〃	〃	2000	900	20	1.2W	150	1	900	50	5	1	10	−1	〃				6 *	1.6		418	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC4032	ローム	RF.AF	Si.EP	40	32	300	300	125	1	24	10000	5	100	5	−10					250*	5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	415	ダーリントン
〃 4033	〃	〃	Si.TP	130	130	30	150	125	1	80	120	3	5	5	−2					60*	6	$C_c r_{bb'}$ 200ps	415	
〃 4034	〃	〃	Si.EP	80	80	50	150	125	1	75	390	6	2	6	−1		10.8k	0.54	4	140*	3	$C_c r_{bb'}$ 120ps	415	
〃 4035	〃	〃	Si.TP	180	180	30	150	125	1	120	120	3	5	5	−2					60*	6	$C_c r_{bb'}$ 200ps	415	
〃 4036	〃	〃	〃	210	210	30	150	125	1	120	120	3	5	5	−2					60*	6	$C_c r_{bb'}$ 200ps	415	
〃 4037	〃	〃	Si.EP	40	32	500	400	125	1	20	180	3	100	5	−20					250*	6.2	$C_c r_{bb'}$ 60ps	415	
〃 4038	〃	RF.AF.LN	〃	50	40	100	300	125	0.5	30	220	6	1	6	−1		13k	0.49	9.6	180*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 120ps	415	
〃 4039	〃	RF.AF	〃	40	25	50	250	125	0.5	24	120	6	1	6	−1					300*	1.6	$C_c r_{bb'}$ 20ps	415	
〃 4040	〃	〃	〃	40	32	1 A	600	125	0.5	20	180	3	100	5	−50					150*	15	$C_c r_{bb'}$ 80ps	415	
〃 4041	〃	RF	〃	30	19	50	300	125	0.5	20	120	10	5	5	−10					1100*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	415	
〃 4042	〃	〃	〃	30	18	50	150	125	0.5	15	70	10	10	10	−10					1500*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 7 ps	138	
〃 4043	〃	〃	〃	20	11	50	150	125	0.5	10	90	10	5	10	−10					3200*	1.0	$C_c r_{bb'}$ 4.5ps	138	
〃 4044	〃	〃	〃	30	20	50	150	125	0.5	15	90	10	5	10	−10					2000*	1.0	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	138	
〃 4045	〃	〃	〃	20	11	50	150	125	0.5	10	90	10	5	10	−10					3200*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 4.5ps	235	
〃 4046	日立	〃	Si.E	120	120	200	1 W	150	100	80	500	10	10	10	−50					350*	3.6	10	160	
〃 4047	三洋	SW	Si.EP	50	50	100	200	150	0.1	40	130	5	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=10kΩ, R_{BE}=47kΩ)						250*	3.7		176	2SA1563とコンプリ
〃 4048	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	130	5	5	〃						250*	3.7		92	2SA1564とコンプリ
〃 4049	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	130	5	5	〃						250*	3.7		92C	2SA1565とコンプリ
〃 4050	日立	RF	Si.E	120	120	100	150	150	0.1	70	400	12	2	6	−10					310*	3	30	176	2SA1566とコンプリ
〃 4051	新電元	SW	Si.TP	600	450	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	600	16	5	1.5A	10	−300	t_{on}<0.5μs, t_f<0.2μs t_{stg}<2 μs				20*			268	T3V45FX
〃 4052	〃	〃	〃	600	450	3 A	25W (Tc=25°C)	150	100	600	16	5	1.5A	10	−300	〃				20*			410	TP3V45FX
〃 4053	〃	〃	〃	600	450	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	600	16	5	2.5A	10	−500	〃				20*			268	T5V45FX
〃 4054	〃	〃	〃	600	450	5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	600	16	5	2.5A	10	−500	〃				20*			410	TP5V45FX
〃 4055	〃	〃	〃	600	450	8 A	60W (Tc=25°C)	150	100	600	16	5	4 A	10	−800	〃				20*			268	T8V45FX
〃 4056	〃	〃	〃	600	450	8 A	45W (Tc=25°C)	150	100	600	16	5	4 A	10	−800	〃				20*			410	TP8V45FX
〃 4057	〃	〃	〃	600	450	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	600	16	5	4 A	10	−800	〃				20*			119	T8W45FX
〃 4058	〃	〃	〃	600	450	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	600	16	5	5 A	10	−1A	〃				20*			119	T10W45FX
〃 4059	〃	〃	〃	600	450	15A	130W (Tc=25°C)	150	100	600	16	5	7.5A	10	−1.5A	〃				20*			119	T15W45FX
〃 4060	〃	〃	〃	600	450	20A	150W (Tc=25°C)	150	100	600	16	5	10A	10	−2A	〃				20*			119	T20W45FX
〃 4061	ローム	RF	〃	300	300	100	200	125	0.5	200	82	10	10	30	−10					100*	3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	176	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ / f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC4062	日電	SW	Si. E	100	100	7 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	800	2	3 A			t_{on}=0.4μs, t_f=0.4μs t_{stg}=1.5μs							96	ダーリントン
〃 4063	〃	〃	〃	100	100	15A	35W (Tc=25°C)	150	10	100	800	2	5 A			t_{on}=0.16μs, t_f=0.4μs t_{stg}=1.6μs							96	〃
〃 4064	サンケン	RF. PA	Si. EP	50	50	12A	40W (Tc=25°C)	150	100	50	150	1	6 A	12	−500					40 *	180	15	400	
〃 4065	〃	〃	〃	60	60	12A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	150	1	6 A	12	−500					40 *	180	15	400	
〃 4066	三洋	SW	〃	50	50	100	200	150	0.1	40	>80	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_{BE}=4.7kΩ±14kΩ)						250 *	3.7		176	2SA1571 とコンプリ
〃 4067	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	>80	5	10	〃						250 *	3.7		92	2SA1572 とコンプリ
〃 4068	松下	RF	〃	30	20	20	150	150	1	25	100	10	3	3.4	−1.8	G_{pe}=10dB, NF=6 dB (800MHz)				1500*	0.7	380	412	
〃 4069	三洋	SW	〃	50	50	100	200	150	0.1	40	>70	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_{BE}=22kΩ±6.6kΩ)						250 *	3.7		176	2SA1573 とコンプリ
〃 4070	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	>70	5	10	〃						250 *	3.7		92	2SA1574 とコンプリ
〃 4071	〃	Diff. SW	〃	30	20	30	250	150	1	20	40~200	10	3	10	−3					1200*	0.7		355	2素子複合
〃 4072	〃	〃	〃	25	16	50	250	150	1	16	40~200	10	5	10	−5					3500*	0.6		355	〃
〃 4073	サンケン	SW	Si. TP	500	400	5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	2 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							400	
〃 4074	ローム	RF.Conv.Mix Osc. PA	Si. EP	30	20	50	150	125	0.5	15	90	10	10	10	−10					1500*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	176A	
〃 4075	三洋	RF. AF. PA	Si. TP	300	300	200	10W (Tc=25°C)	150	0.1	200	120	10	10	30	−10					>50*	<5.3		388	
〃 4076	ローム	RF. AF	Si. EP	60	50	150	200	150	0.5	30	220	6	1	12	−2					180 *	2	$C_c r_{bb'}$ 120ps	176	
〃 4077	〃	AF. LN	〃	30	30	100	300	150	0.5	18	220	6	1	12	−2	NF=3 dB (6 V, 0.1mA, 120Hz)				230 *	1.8		138	
〃 4078	〃	〃	〃	30	30	100	300	150	0.5	18	220	6	1	12	−2	〃				230 *	1.8		235	
〃 4079	〃	〃	〃	30	30	100	200	150	0.5	18	220	6	1	12	−2	〃				230 *	1.8		176	
〃 4080	三洋	RF	〃	200	200	100	500	150	0.1	150	100	10	10	30	−30					400 *	1.8	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	336	
〃 4081	ローム	RF. AF	〃	50	40	100	200	125	0.5	30	270	6	1	12	−2					180 *	2	$C_c r_{bb'}$ 120ps	412	
〃 4082	〃	RF.Conv.Mix Osc. PA	〃	30	20	50	150	125	0.5	15	85	10	10	10	−10					1500*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	412	
〃 4083	〃	〃	〃	20	11	50	150	125	0.5	10	85	10	5	10	−10					3200*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	412	
〃 4084	〃	〃	〃	30	20	50	150	125	0.5	15	90	10	5	10	−5					2000*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 3.5ps	412	
〃 4085	日電	RF	Si. E	30	25	20	150	125	0.1	25	120	10	3	10	−3					1000*	0.65	$C_c r_{bb'}$ 10ps	144B	
〃 4086	〃	〃	〃	30	15	50	150	125	0.1	12	100	10	5	10	−5					2000*	1	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	144B	
〃 4087	〃	〃	〃	30	14	50	150	125	0.1	15	100	10	5	10	−5					2000*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	144B	
〃 4088	〃	〃	〃	15	8	5	50	150	0.1	5	100	1	0.25	1	−1					4000*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 20ps	144B	
〃 4089	〃	〃	〃	25	12	30	200	150	0.1	10	100	10	5	10	−5					4000*	0.95	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	144B	
〃 4090	〃	〃	〃	30	14	50	150	125	0.1	15	100	10	5	10	−5					2000*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	144A	
〃 4091	〃	〃	〃	15	8	5	50	150	0.1	5	100	1	0.25	1	−1					4000*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 20ps	144A	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC4092	日電	RF	Si. E	25	12	70	250	150	1	15	100	10	20	10	−20	MAG=14.5dB (f=1 GHz)				6000*	0.95	$C_c r_{bb'}$ 4 ps	144A	
〃 4093	〃	〃	〃	20	12	100	200	150	1	10	120	10	20	10	−20					6500*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 5 ps	144A	
〃 4094	〃	〃	〃	20	10	65	200	150	1	10	120	8	20	8	−20	MAG=17dB (f=1 GHz)				9000*	0.6	$C_c r_{bb'}$ 10ps	144A	
〃 4095	〃	〃	〃	20	10	35	200	150	1	10	100	6	10	6	−10	MAG=12dB (f=2 GHz)				10000*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 10ps	144A	
〃 4096	松下	SW	Si. TP	1400	800	10A	150W (T_c=25°C)	150	100	1400	10	5	7 A			t_{on}<1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3.5μs							393	
〃 4097	ローム	AF	Si. EP	40	32	500	200	125	1	20	180	3	10	5	−20					250*	6	$C_c r_{bb'}$ 60ps	412	
〃 4098	〃	RF. AF	〃	40	25	50	200	125	0.5	24	120	6	1	6	−1					300*	1.3	$C_c r_{bb'}$ 20ps	412	
〃 4099	〃	RF	〃	25	20	20	150	125	0.5	20	82	6	1	6	−1					500*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 16ps	412	
〃 4100	〃	〃	〃	30	18	50	200	125	0.5	20	120	10	5	5	−10					1100*	1	$C_c r_{bb'}$ 10ps	412	
〃 4101	〃	RF. LN	〃	120	120	50	200	125	0.5	100	390	6	2	12	−2	NF=0.2dB (6 V, −0.1mA, 100Hz)				140*	3	$C_c r_{bb'}$ 120ps	412	
〃 4102	〃	〃	〃	120	120	50	200	125	0.5	100	300	6	2	12	−2	〃				140*	3	$C_c r_{bb'}$ 120ps	412	
〃 4103	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	30	25	30	200	125	0.1	25	120	10	4	10	−4					1100*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 10ps	412	
〃 4104	三洋	RF	〃	70	60	50	200	150	0.1	40	200	10	10	10	−10					700*	1.3	$C_c r_{bb'}$ 8 ps	176	
〃 4105	〃	SW	Si. TP	500	400	4 A	40W (T_c=25°C)	150	10	400	30	5	400	10	−400	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.5μs				20*	50		268	
〃 4106	〃	〃	〃	500	400	7 A	50W (T_c=25°C)	150	10	400	30	5	800	10	−800	〃				20*	80		268	
〃 4107	〃	〃	〃	500	400	10A	60W (T_c=25°C)	150	10	400	30	5	1.2A	10	−1.2A	〃				20*	120		268	
〃 4108	〃	〃	〃	500	400	12A	100W (T_c=25°C)	150	10	400	30	5	1.6A	10	−1.6A	〃				20*	160		346	
〃 4109	〃	〃	〃	500	400	16A	140W (T_c=25°C)	150	10	400	30	5	2 A	10	−2A	〃				20*	230		346	
〃 4110	〃	〃	〃	500	400	25A	160W (T_c=25°C)	150	10	400	30	5	3.2A	10	−3.2A	〃				20*	300		346	
〃 4111	松下	〃	〃	1500	700	10A	150W (T_c=25°C)	150	1 mA	1500	7	5	7 A			t_{on}<1 μs, t_f<0.6μs t_{stg}<12μs							393	
〃 4112	三洋	〃	Si. EP	50	50	100	200	150	0.1	40	300	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ)						250*	3.7		176	2SA1581 とコンプリ
〃 4113	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	300	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=2.2k±0.7kΩ)						250*	3.7		92	2SA1582 とコンプリ
〃 4114	松下	〃	Si. TP	600	550	100	1 W (T_c=25°C)	150	100	600	100	5	10			t_{on}<2 μs, t_f<1.5μs t_{stg}<4 μs							336	
〃 4115	ローム	AF. PA. SW	Si. EP	20	20	2 A	400	150	0.1	20	330	3	100			t_{on}<1 μs, t_f<1.5μs t_{stg}<2.5μs							406	
〃 4116	東芝	RF. AF	〃	60	50	150	100	125	0.1	60	200	6	2	10	−1					150*	2	50	412	
〃 4117	〃	RF. AF. LN	〃	120	120	100	100	125	0.1	120	350	6	2	6	−1	NF=1 dB (6 V, −0.1mA, 1 kHz)				100*	3	18	412	
〃 4118	〃	RF. AF	〃	35	30	500	100	125	0.1	35	200	1	0.1	6	−20					300*	7	20	412	
〃 4119	三洋	SW	Si. TP	1500	800	15A	250W (T_c=25°C)	150	100	800	100	5	15A			t_{on}<2 μs, t_f<2 μs t_{stg}<7 μs							224	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 4120	〃	〃	Si. EP	50	50	100	200	150	0.1	40	300	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=22k±7kΩ)						250*	3.7		176	2SA1589 とコンプリ
〃 4121	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	300	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=22k±7kΩ)						250*	3.7		92	2SA1590 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ / f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC4122	三洋	SW	Si.TP	1500	800	6 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.2μs t_{stg}< 3 μs							397	ダンパ内蔵
〃 4123	〃	〃	〃	1500	800	7 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 4124	〃	〃	〃	1500	800	8 A	70W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 4125	〃	〃	〃	1500	800	10A	70W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 4126	日立	RF	Si.E	15	11	50	150	150	1	12	120	5	20	5	−20	G_{pe}=11dB (900MHz)		NF=1.5dB (5 mA, 900MHz)		6000*	1	50 *	408A	
〃 4127	〃	〃	〃	15	10	50	150	150	1	12	120	5	20	5	−20	G_{pe}=12dB (900MHz)		NF=1.2dB (5 mA, 900MHz)		7500*	0.9	50 *	408A	
〃 4128	ローム	RF.AF	Si.EP	50	40	100	250	125	0.5	24	180	6	2	6	−2					230 *	1.8	$C_c r_{bb'}$ 22ps	412	
〃 4129	〃	SW	Si.TP	400	400	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	400	25	5	3 A	10	−500	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs				15 *	80		405	
〃 4130	サンケン	〃	〃	500	400	7 A	30W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							400	
〃 4131	〃	PA	Si.EP	100	50	15A	60W (Tc=25°C)	150	10	100	200	0.5	5 A	12	−500					20 *	210	12	172	
〃 4132	ローム	SW	〃	120	120	2 A	500	150	1	80	200	5	500										336	
〃 4133	三洋	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	150	5	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_B/R_{BE}=0.1±0.01)						250 *	3.7		92	2SA1591 とコンプリ
〃 4134	〃	RF	〃	120	100	1 A	10W (Tc=25°C)	150	0.1	100	200	5	100	10	−100					120 *	8.5	$C_c r_{bb'}$ 30ps	411	2SA1592 とコンプリ
〃 4135	〃	〃	〃	120	100	2 A	15W (Tc=25°C)	150	0.1	100	200	5	100	10	−100					120 *	16	$C_c r_{bb'}$ 30ps	411	2SA1593 とコンプリ
〃 4136	富士電機	SW	Si.TP	200	120	20A	140W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	40	5	20A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							102	
〃 4137	ローム	RF.AF	Si.EP	25	20	100	1 W	150	0.5	15	1200	10	20	10	−10					300 *	3	$C_c r_{bb'}$ 200ps	244	
〃 4138	サンケン	SW	Si.TP	500	400	10A	80W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	6 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							324	
〃 4139	〃	〃	〃	500	400	15A	120W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	8 A			〃							324	
〃 4140	〃	〃	〃	500	400	18A	130W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	10A			〃							324	
〃 4141	ローム	RF.AF	Si.EP	60	50	100	200	150	0.5	60	220	6	1	12	−2					180 *	2	$C_c r_{bb'}$ 120ps	412	
〃 4142	日立	SW	Si.T	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	500	1200	15	5	300			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 4 μs							417	
〃 4143	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	50W (Tc=25°C)	150	500	1200	10	5	1 A			〃							417	
〃 4144	〃	〃	〃	1300	500	8 A	50W (Tc=25°C)	150	500	1300	15	5	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.4μs t_{stg}< 3 μs							417	
〃 4145	ローム	AF.SW	Si.EP	80	80	2 A	1.2W	150	1	80	180	3	500			t_{on}< 1 μs, t_f<1.5μs t_{stg}<2.5μs							294	
〃 4146	三洋	SW	〃	50	50	100	200	150	0.1	40	150	5	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_B/R_{BE}=0.1±0.01)						250 *	3.5		176	2SA とコ
〃 4147	ローム	RF	Si.TP	300	300	100	5 W (Tc=25°C)	150	0.5	200	82	10	10	30	−10					100 *	3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	244	
〃 4148	新電元	SW	Si.EP	60	40	7 A	25W (Tc=25°C)	150	100	60	170	2	3.5A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							410	
〃 4149	〃	〃	〃	60	40	10A	25W (Tc=25°C)	150	100	60	170	2	5 A			〃							410	
〃 4150	〃	〃	〃	60	40	12A	25W (Tc=25°C)	150	100	60	170	2	6 A			〃							410	
〃 4151	〃	〃	〃	60	40	15A	30W (Tc=25°C)	150	100	60	170	2	7.5A			〃							410	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC4152	松下	SW	Si.TP	1400	700	300	20W (Tc=25°C)	150	10	1100	30	5	30			t_{on}< 2 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							364	
〃 4153	サンケン	〃	〃	200	120	7 A	30W (Tc=25°C)	150	100	200	120	4	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							400	
〃 4154	三菱	RF.AF	Si.E	50	50	200	150	125	0.1	50	300	6	1	6	−10					200*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 300ps	412	
〃 4155	〃	〃	〃	50	50	100	150	125	0.5	50	300	6	1	6	−10					200*	2	$C_c r_{bb'}$ 240ps	412	
〃 4156	三洋	Diff	Si.EP	60	50	500	200/unit	150	0.1	40	300	5	10	10	−50	ΔV_{BE}<10mV $\gamma\Delta V_{BE}$<50mV/°C				300*	3.7	$C_c r_{bb'}$ 300ps	355	2素子複合
〃 4157	東芝	SW	Si.TP	600	450	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	22	5	5 A			t_r<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs							203	
〃 4158	松下	RF.Conv.Mix Osc.PA	Si.EP	250	250	100	2 W	150	10	200	100	10	30	10	−10					300*	2.2		364	
〃 4159	三洋	SW	〃	180	160	1.5A	15W (Tc=25°C)	150	10	120	100	5	300	10	−50	t_{on}< 1 μs, t_f< 3 μs t_{stg}< 1 μs				100*	23		388	2SA1606とコンプリ
〃 4160	〃	〃	Si.TP	500	400	4 A	25W (Tc=25°C)	150	10	400	30	5	400	10	−400	t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.5μs				20*	50		388	
〃 4161	〃	〃	〃	500	400	7 A	30W (Tc=25°C)	150	10	400	30	5	800	10	−800	〃				20*	80		388	
〃 4162	〃	〃	〃	500	400	10A	35W (Tc=25°C)	150	10	400	30	5	1.6A	10	−1.6A	〃				20*	120		388	
〃 4163	〃	〃	〃	500	400	12A	40W (Tc=25°C)	150	10	400	30	5	1.6A	10	−1.6A	〃				20*	160		388	
〃 4164	〃	〃	〃	500	400	12A	70W (Tc=25°C)	150	10	400	30	5	1.6A	10	−1.6A	〃				20*	160		268	
〃 4165	日立	RF	Si.E	300	300	200	1.25W	150	1	250	200	5	10	20	−40					130*	4	$C_c r_{bb'}$ 40ps	160	
〃 4166	ローム	SW	Si.TP	400	400	100	900	150	10	400	100	10	10	10	−10	t_{on}< 1 μs, t_f<1.7μs t_{stg}<5.5μs				20*	7		294	
〃 4167	三菱	PA	Si.EP	35	17	2 A	20W (Tc=25°C)	175	500	15	50	10	100			P_o= 8 W, η=60% (f=520MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=1.2W)							154	
〃 4168	三洋	SW	〃	40	20	150	200	150	0.1	30	150	1	10	10	−10	t_r<20ns, t_f<25ns t_{stg}<180ns				700*	2.6		176	2SA1607とコンプリ
〃 4169	〃	〃	〃	50	50	1.2A	1 W	150	10	40	4000	5	500			t_{on}<0.2μs, t_f<0.4μs t_{stg}<2.2μs							294	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 4170	〃	RF	〃	50	40	50	200	150	0.1	40	150	5	10	6	− 2					180*	5	60	212	E回路にZD接続
〃 4171	〃	SW	Si.TP	800	500	3 A	40W (Tc=25°C)	150	10	500	30	5	300	10	−300	t_{on}< 1 μs, t_f< 1μs t_{stg}< 3 μs				18*	40		418	
〃 4172	〃	〃	〃	800	500	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	30	5	600	10	−700	〃				18*	80		418	
〃 4173	日電	〃	Si.E	60	40	500	150	150	0.1	40	150	1	150			t_{on}<35ns, t_{off}<275ns t_{stg}<225ns							412	
〃 4174	〃	RF.AF	〃	180	160	50	150	150	0.1	130	200	3	15	10	−10					120*	2.3	15	412	
〃 4175	〃	SW	〃	40	20	200	150	150	0.1	30	80	0.5	1			t_{on}<20ns, t_{off}<40ns t_{stg}<20ns							412	
〃 4176	〃	〃	〃	40	15	200	150	150	0.1	20	90	1	10			t_{on}<12ns, t_{off}<18ns t_{stg}<13ns							412	
〃 4177	〃	RF.AF	〃	60	50	100	150	150	0.1	60	200	6	1	6	−10					250*	3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	412	
〃 4178	〃	SW	〃	30	20	20	150	150	0.1	30	90	6	1	6	− 1					600*	1	$C_c r_{bb'}$ 12ps	412	
〃 4179	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	50	30	50	150	150	0.1	30	90	6	1	6	− 1	NF= 2 dB (f= 1 MHz)				250*	1.9	$C_c r_{bb'}$ 10ps	412	
〃 4180	〃	RF.AF	〃	120	120	50	150	150	0.05	120	600	6	1	6	− 1					110*	1.6	50	412	
〃 4181	〃	SW	〃	60	50	150	150	150	0.1	50	1800	5	1			t_{on}< 1 μs, t_{off}< 2 μs t_{stg}< 2 μs							412	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC4182	日電	Osc	Si. E	30	15	50	150	125	0.1	12	120	10	5	3	−5					900*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 16ps	412	
〃 4183	〃	RF	〃	30	25	20	150	125	0.1	25	120	5	3	5	−3					900*	0.6	$C_c r_{bb'}$ 7 ps	412	
〃 4184	〃	Conv	〃	30	15	50	150	125	0.1	12	100	10	5	3	−5					1500*	0.6	$C_c r_{bb'}$ 10ps	412	
〃 4185	〃	Mix	〃	30	14	50	150	125	0.1	15	100	10	5	3	−5					1600*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	412	
〃 4186	〃	Osc	〃	25	12	30	150	125	0.1	10	100	10	3	10	−3					2000*	1.2	$C_c r_{bb'}$ 10ps	412	
〃 4187	〃	RF	〃	15	8	5	50	125	0.1	5	100	1	0.25	1	−1	NF=3.5dB (1 V, 250μA, 1 GHz)				3000*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 15ps	412	
〃 4188	三洋	〃	Si. EP	200	200	100	10W (Tc=25°C)	150	0.1	150	100	10	10	30	−10					150*	1.8	$C_c r_{bb'}$ 15ps	268	
〃 4189	ローム	〃	Si. TP	300	300	100	500	150	0.5	200	82	10	10	30	−10					100*	3	$C_c r_{bb'}$ 100ps	336	
〃 4190	松下	PA	Si. EP	65	40	300	2 W	150	10	48	80	10	50	10	−50					>1500*	2.4		364	
〃 4191	シャープ	SW	Si. TP	500	400	2 A	20W (Tc=25°C)	150	100	400	>10	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							268	
〃 4192	〃	〃	〃	500	400	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	1.5A			〃							268	
〃 4193	〃	〃	〃	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	2.5A			〃							268	
〃 4194	〃	〃	〃	500	400	7 A	50W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	3.5A			〃							268	
〃 4195	三洋	〃	Si. EP	50	50	100	300	150	0.1	40	150	5	5	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_B/R_{BE}=0.1±0.01)						250*	3.7		92C	2SA1616とコンプリ
〃 4196	日立	Osc	Si. E	25	15	50	150	150	0.3	15	90	5	5	5	−20	V_{osc}=200mV (5 V, 5 mA, 930MHz)				2400*	0.7	70*	176	
〃 4197	〃	RF.Conv.Mix	〃	25	13	50	150	150	0.1	15	100	5	5	5	−20					3800*	0.7	30*	176	
〃 4198	ローム	RF. AF	Si. EP	25	20	800	1 W	150	0.5	15	820	10	20	10	−10					200*	8	$C_c r_{bb'}$ 100ps	244	
〃 4199	サンケン	SW	Si. TP	1400	800	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	1200	8	4	5 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 4 μs							172	○
〃 4200	東芝	RF	Si. EP	20	18	600	5 W (Tc=25°C)	150	1	20	120	10	50	10	−200					2200*	4	70	384	
〃 4201	〃	〃	〃	100	100	500	30W (Tc=25°C)	150	100	100	120	10	100	10	−100					1000*	5	10	268	
〃 4202	〃	〃	〃	100	100	500	30W (Tc=25°C)	150	100	100	120	10	100	10	−100					1000*	5	10	268	
〃 4203	〃	〃	〃	180	150	500	10W (Tc=25°C)	150	10	150	120	10	50	10	−100					400*	4	15	137	
〃 4204	三洋	〃	〃	30	25	700	600	150	0.1	20	1500	5	50	10	−50					270*	9	$C_c r_{bb'}$ 150ps	138	
〃 4205	ローム	SW	Si. TP	400	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	10	400	25	5	3 A	10	−500	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs				15*	80		268	
〃 4206	富士電機	〃	〃	900	600	6 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	15	5	2 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							211	
〃 4207	東芝	RF. AF	Si. EP	60	50	150	100	125	0.1	60	350	6	2	10	−1					150*	2	50	73	2素子複合
〃 4208	松下	〃	〃	30	25	500	1 W	150	0.1	20	210	10	150	10	−50					150*	6	30	413	
〃 4209	東芝	〃	〃	70	60	200	200	150	0.1	20	130	2	50	2	−50					150*	6	5	176	
〃 4210	〃	〃	〃	30	25	800	200	150	0.1	20	200	1	100	5	−10					120*	13	25	176	
〃 4211	三洋	RF	〃	55	50	150	100	150	0.1	35	400	6	1	6	−1					180*	3	$C_c r_{bb'}$ 250ps	412	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC4212	松下	SW	Si.TP	350	300	200	1.2W	150	2	200	150	10	10			t_{on}<6μs, t_f<3μs t_{stg}<7.5μs							222	
〃 4213	東芝	RF.AF.SW	Si.EP	50	20	300	100	125	0.1	50	600	2	4	2	−4	t_{on}<300ns, t_f<200ns t_{stg}<800ns				30*	4.8	40	412	
〃 4214	〃	RF	Si.P	25	20	20	150	125	0.1	10	120	3	1	3	−1	G_{pb}=15dB (f=800MHz)				850*	0.6	$C_c r_{bb'}$ 10ps	394B	
〃 4215	〃	〃	Si.EP	40	30	20	100	125	0.5	40	100	6	1	6	−1					550*	1	$C_c r_{bb'}$ 15ps	412	
〃 4216	三洋	SW	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	250	5	10	バイアス抵抗内蔵型 (R_B=4.7k±1.4kΩ)									92C	
〃 4217	〃	RI	Si.T	300	300	200	10W (T_c=25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	−10					80*	4	200*	389	
〃 4218	〃	〃	Si.EP	250	250	100	500	150	0.1	200	190	10	1	30	−10					70*	1.5	$C_c r_{bb'}$ 10ps	138	
〃 4219	〃	SW	Si.TP	500	400	4A	40W (T_c=25°C)	150	10	400	30	5	400			t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.5μs							418	
〃 4220	〃	〃	〃	500	400	7A	50W (T_c=25°C)	150	10	400	30	5	800			〃							418	
〃 4221	〃	〃	〃	800	500	3A	40W (T_c=25°C)	150	10	500	30	5	300			t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3μs							418	
〃 4222	〃	〃	〃	800	500	5A	50W (T_c=25°C)	150	10	500	30	5	600			t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3μs							418	
〃 4223	〃	〃	〃	1100	800	1.5A	40W (T_c=25°C)	150	10	800	20	5	100			〃							418	
〃 4224	〃	〃	〃	1100	800	3A	50W (T_c=25°C)	150	10	800	20	5	200			〃							418	
〃 4225																								
〃 4226																								
〃 4227																								
〃 4228																								
〃 4229	日立	RF	Si.E	30	25	20	150	150	0.3	15	120	5	2	5	−2	G_{pe}=15dB, NF=3dB (4V, 2mA, 900MHz)				1000*	0.5	20*	176	
〃 4230	新電元	SW	Si.TP	1200	800	2A	50W (T_c=25°C)	150	100	1200	13	5	1A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<3.5μs							268	
〃 4231	〃	〃	〃	1200	800	2A	30W (T_c=25°C)	150	100	1200	13	5	1A			〃							410	
〃 4232	〃	〃	〃	1200	800	2A	70W (T_c=25°C)	150	100	1200	13	5	1A			〃							119	
〃 4233	〃	〃	〃	1200	800	3A	60W (T_c=25°C)	150	100	1200	13	5	1.5A			〃							268	
〃 4234	〃	〃	〃	1200	800	3A	45W (T_c=25°C)	150	100	1200	13	5	1.5A			〃							410	
〃 4235	〃	〃	〃	1200	800	3A	80W (T_c=25°C)	150	100	1200	13	5	1.5A			〃							119	
〃 4236	〃	〃	〃	1200	800	6A	100W (T_c=25°C)	150	100	1200	13	5	3A			〃							119	
〃 4237	〃	〃	〃	1200	800	10A	150W (T_c=25°C)	150	100	1200	13	5	5A			〃							119	
〃 4238	松下	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	30	20	50	150	150	50	10	180	10	2	10	−1.5	G_{pe}=20dB (10V, 1mA, 100MHz)				1200*	1	680	412	
〃 4239	〃	RF.Mix	〃	15	10	50	150	125	1	10	200	4	5	4	−5					1900*	1.4	$C_c r_{bb'}$ 11ps	412	
〃 4240	三菱	PA	〃	20	9	3A	20W (T_c=25°C)	175	500	10	50	5	100			P_o=7W, η=65% (f=1.75MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=0.3W)							154	
〃 4241	日電	Mix.Osc	Si.E	20	12	80	200	150	1	10	120	10	20	10	−20					6500*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 10ps	144B	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC4242	富士電機	SW	Si. T	450	400	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	450	15	5	4 A			t_{on}<1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs							268	
〃 4243																								
〃 4244	東芝	RF	Si. P	25	20	20	100	125	0.1	10	100	3	1	3	−1					850*	0.6	$C_c r_{bb'}$ 10ps	412	
〃 4245	〃	RF. Conv	Si. EP	30	15	50	100	125	0.1	30	100	10	5	10	−2	G_{ce}=17dB (10V, 2 mA, 800MHz)				2400*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 14ps	412	
〃 4246	〃	Osc	〃	30	15	50	100	125	0.1	15	150	3	8	10	−8					1500*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 7 ps	412	
〃 4247	〃	〃	〃	20	12	30	100	125	0.1	10	70	10	5	10	−10					4000*	1.05	$C_c r_{bb'}$ 4.5ps	412	
〃 4248	〃	〃	〃	20	12	30	100	125	0.1	10	150	10	5	10	−10					4000*	1.05	$C_c r_{bb'}$ 4.5ps	412	
〃 4249	〃	RF	Si. P	30	30	20	100	125	0.1	25	150	10	2	10	−2	G_{pe}=24dB (10V, 2 mA, 200MHz)				650*	0.75	$C_c r_{bb'}$ 11.5ps	412	
〃 4250	〃	RF. Conv	Si. EP	30	20	50	100	125	0.1	25	150	10	5	10	−5	G_{ce}=23dB (9 V, 3 mA, 200MHz)				1400*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 6 ps	412	
〃 4251	〃	Osc	〃	30	15	50	100	125	0.1	15	100	3	8	10	−8					1100*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 7 ps	412	
〃 4252	〃	〃	〃	20	12	30	100	125	0.1	10	100	10	5	10	−5					2000*	1.05	$C_c r_{bb'}$ 4.5ps	412	
〃 4253	〃	RF	〃	30	25	50	100	125	0.1	30	70	10	10	10	−10					600*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 10ps	412	
〃 4254	日立	RF. AF	〃	50	40	100	100	150	0.5	30	300	12	2	12	−2					230*	2	100	412	
〃 4255	東芝	Osc	〃	20	12	30	150	125	0.1	20	100	10	5	10	−5					2000*	1.05	$C_c r_{bb'}$ 4.3ps	176	
〃 4256	三洋	AF. PA	Si. TP	1500	1200	10	5 W (Tc=25°C)	150	1	1200	30	5	0.5										268	
〃 4257	〃	〃	〃	1500	1200	30	7 W (Tc=25°C)	150	1	1200	30	5	1.5										268	
〃 4258	三菱	RF	Si. E	30	25	30	150	125	1	30	80	6	1	6	−1					200*	2	$C_c r_{bb'}$ 20ps	412	
〃 4259	日立	〃	〃	30	25	20	100	150	0.3	15	120	5	2	5	−2	G_{pe}=15dB, NF=3 dB (4 V, 2 mA, 900MHz)				1000*	0.6	20*	412	
〃 4260	〃	Conv	〃	25	13	50	100	150	0.1	15	100	5	5	5	−20	G_{ce}=19dB (5 V, 0.8mA, 900MHz)				3800*	0.85	30*	412	
〃 4261	〃	Osc	〃	25	15	50	100	150	0.3	15	90	5	5	5	−20	V_{osc}=200mV (5 V, 5 mA, 930MHz)				2400*	0.7	70*	412	
〃 4262	〃	〃	〃	20	15	50	100	150	0.5	15	120	10	5	10	−5	V_{osc}=200mV (12V, 7 mA, 930MHz)				2500*	0.75	$C_c r_{bb'}$ 2 ps	412	
〃 4263	〃	RF	〃	15	12	20	100	150	0.3	12	110	4	2	4	−2	NF=2 dB (6 V, 2 mA, 200MHz)				1000*	0.8	$C_c r_{bb'}$ 10ps	412	
〃 4264	〃	Conv	〃	20	11	50	100	150	0.5	10	90	10	10	10	−10	G_{ce}=15dB (10V, 2 mA, 900MHz)				3500*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 10ps	412	
〃 4265	〃	Osc	〃	30	20	50	100	150	0.5	10	100	10	10	10	−10	V_{osc}=210mV (12V, 7 mA, 300MHz)				1000*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 10ps	412	
〃 4266	三菱	RF. AF	〃	50	50	100	500	125	0.5	50	300	6	1	6	−10					200*	2	$C_c r_{bb'}$ 240ps	175	
〃 4267																								
〃 4268																								
〃 4269	三洋	RF	Si. EP	30	15	50	250	150	0.1	20	100	10	5	10	−10					1200*	0.75	$C_c r_{bb'}$ 2 ps	176	
〃 4270	〃	〃	〃	25	15	50	250	150	0.1	20	100	10	5	10	−10					3000*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 2 ps	176	
〃 4271	〃	〃	〃	30	20	300	5 W (Tc=25°C)	150	0.1	20	100	5	50	5	−100					3000*	3.9	$C_c r_{bb'}$ 3 ps	296	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ r_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC4272	三洋	PA	Si. EP	75	45	1 A	1.3W (Tc=25°C)	150	1	40	150	5	500	10	−500					250 *	15	$C_c \mid r_{bb'}$ 20ps	336	
〃 4273	富士電機	SW	Si. TP	500	400	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	450	40	5	500			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}<2.5μs							268	
〃 4274	〃	〃	〃	500	400	10A	40W (Tc=25°C)	150	100	450	40	5	1 A			〃							268	
〃 4275	〃	〃	〃	500	400	10A	80W (Tc=25°C)	150	100	450	40	5	1 A			〃							211	
〃 4276	〃	〃	〃	500	400	15A	80W (Tc=25°C)	150	100	450	40	5	2 A			〃							211	
〃 4277	ローム	〃	〃	500	400	5 A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	25	5	3 A			〃							334	
〃 4278	〃	〃	〃	150	150	10A	100W (Tc=25°C)	150	10	150	180	5	1 A	5	−1A					30 *	230	15	334	
〃 4279																								
〃 4280																								
〃 4281																								
〃 4282																								
〃 4283																								
〃 4284	東芝	SW	Si. TP	1400	600	8 A	150W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A	10	−500	t_{on}< 1 μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 4 μs				5 *			102	
〃 4285	〃	〃	〃	1400	600	10A	150W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A	10	−500	〃				7 *			102	
〃 4286	〃	〃	〃	1400	600	8 A	100W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A	10	−500	〃				5 *			380	
〃 4287	〃	〃	〃	1400	600	10A	100W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A	10	−500	〃				5 *			380	
〃 4288	〃	〃	〃	1400	600	12A	200W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A	10	−500	t_{on}< 1 μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 5 μs				5 *			152	
〃 4289	〃	〃	〃	1400	600	16A	200W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	3 A	10	−500	〃				5 *			152	
〃 4290	〃	〃	〃	1400	600	20A	200W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A	10	−500	〃				5 *			152	
〃 4291	三洋	〃	〃	1500	800	5 A	100W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 3 μs							346	ダンパ内蔵
〃 4292	〃	〃	〃	1500	800	6 A	100W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							346	〃
〃 4293	〃	〃	〃	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							346	〃
〃 4294	〃	〃	〃	1500	800	6 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							346	〃
〃 4295	ローム	〃	〃	400	400	100	900	150	10	400	120	10	10			t_{on}< 1 μs, t_f< 2 μs t_{stg}< 5 μs							360	
〃 4296	サンケン	〃	〃	500	400	10A	75W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	6 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							172	
〃 4297	〃	〃	〃	500	400	12A	75W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	7 A			〃							172	
〃 4298	〃	〃	〃	500	400	15A	80W (Tc=25°C)	150	100	500	15	4	8 A			〃							172	
〃 4299	〃	〃	〃	900	800	3 A	70W (Tc=25°C)	150	100	800	15	4	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 5 μs							172	
〃 4300	〃	〃	〃	900	800	5 A	75W (Tc=25°C)	150	100	800	15	4	2 A			〃							172	
〃 4301	〃	〃	〃	900	800	7 A	80W (Tc=25°C)	150	100	800	15	4	3 A			〃							172	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC4302	サンケン	SW	Si. TP	900	800	5 A	75W (Tc=25°C)	150	100	800	15	4	1.5A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 4 μs							172	
〃 4303	〃	〃	〃	1400	800	6 A	80W (Tc=25°C)	150	100	1200	8	4	2.5A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 4 μs							172	
〃 4304	〃	〃	〃	900	800	3 A	35W (Tc=25°C)	150	100	800	15	4	700			t_{on}< 1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}< 4 μs							400	
〃 4305	日電	〃	Si. E	100	40	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	40	120	1	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							370	
〃 4306	三洋	〃	Si. EP	30	20	8 A	10W (Tc=25°C)	150	1	20	200	2	500			t_{on}<0.3μs, t_f<0.15μs t_{stg}< 1 μs							411	
〃 4307																								
〃 4308	日立	RF	Si. E	30	20	300	600	150	10	25	100	5	50	5	−50					2500*	4	25 *	138C	
〃 4309	松下	SW	Si. TP	1000	800	6 A	150W (Tc=25°C)	150	100	1000	15	5	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.13μs t_{stg}< 2 μs							393	
〃 4310	新電元	〃	〃	900	800	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	900	13	2	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							268	ダーリントン
〃 4311	〃	〃	〃	900	800	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	900	13	2	3 A			〃							410	〃
〃 4312	〃	〃	〃	900	800	6 A	80W (Tc=25°C)	150	100	900	13	2	3 A			〃							119	〃
〃 4313	〃	〃	〃	900	800	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	900	13	2	5 A			〃							119	〃
〃 4314	〃	〃	〃	900	800	15A	130W (Tc=25°C)	150	100	900	13	2	7.5A			〃							119	〃
〃 4315	東芝	RF	Si. E	20	12	80	150	125	1	10	100	10	20	10	−20	NF=1.1dB (10V, 5 mA, 1 GHz)				7000*	1	30 *	394A	
〃 4316																								
〃 4317																								
〃 4318																								
〃 4319																								
〃 4320																								
〃 4321																								
〃 4322																								
〃 4323																								
〃 4324																								
〃 4325																								
〃 4326	ローム	RF.Conv.Mix Osc	Si. EP	12	8	50	150	125	0.5	10	220	6	5	6	−10					800*	1.1	$C_c r_{bb'}$ 20ps	176	
〃 4327	サンケン	PA	〃	50	35	7 A	25W (Tc=25°C)	150	10	50	70	2	5 A	12	−1A					115*	100	18	400	
〃 4328	日電	SW	Si. E	150	100	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	200	2	1 A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs							268	
〃 4329	〃	〃	〃	150	100	7 A	35W (Tc=25°C)	150	10	100	200	2	1.5A			〃							268	
〃 4330	〃	〃	〃	150	100	10A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	200	2	2 A			〃							268	
〃 4331	〃	〃	〃	150	100	5 A	15W (Tc=25°C)	150	10	100	200	2	1 A			〃							186	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルスh_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC4332	日電	SW	Si. E	100	60	5 A	15W (Tc=25°C)	150	10	60	200	2	1 A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							186	
〃 4333	〃	〃	〃	40	30	7 A	15W (Tc=25°C)	150	10	30	200	2	1.5A			〃							186	
〃 4334	〃	〃	〃	150	100	5 A	25W (Tc=25°C)	150	10	100	200	2	1 A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs							96	
〃 4335	〃	〃	〃	150	100	7 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	200	2	1.5A			〃							96	
〃 4336	〃	〃	〃	150	100	10A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	200	2	2 A			〃							96	
〃 4337	〃	〃	〃	60	60	1 A	7 W (Tc=25°C)	150	10	60	10000	2	500			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							186	ダーリントン
〃 4338	〃	〃	〃	80	80	2 A	8 W (Tc=25°C)	150	1	80	10000	2	1 A			t_{on}<1.2μs, t_f<1.2μs t_{stg}< 4 μs							186	〃
〃 4339	〃	〃	〃	150	100	3 A	9 W (Tc=25°C)	150	1	100	10000	2	1.5A			〃							186	〃
〃 4340	〃	〃	〃	60	60	1 A	8 W (Tc=25°C)	150	1	60	10000	2	500			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 3 μs							225	〃
〃 4341	〃	〃	〃	80	80	2 A	10W (Tc=25°C)	150	1	80	10000	2	1 A			t_{on}<1.2μs, t_f<1.2μs t_{stg}< 4 μs							225	〃
〃 4342	〃	〃	〃	150	100	3 A	12W (Tc=25°C)	150	10	100	10000	2	1.5A			〃							225	〃
〃 4343	〃	〃	〃	150	100	7 A	18W (Tc=25°C)	150	10	100	200	2	1.5A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs							186	
〃 4344	〃	〃	〃	100	60	7 A	18W (Tc=25°C)	150	10	60	200	2	1.5A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs							186	
〃 4345	〃	〃	〃	100	100	5 A	12W (Tc=25°C)	150	1	100	10000	2	2 A			t_{on}<1.2μs, t_f<1.2μs t_{stg}< 4 μs							186	ダーリントン
〃 4346	〃	〃	〃	500	400	5 A	18W (Tc=25°C)	150	10	400	50	5	500			t_{on}<0.7μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.5μs							186	
〃 4347	〃	〃	〃	60±10	60±10	5 A	25W (Tc=25°C)	150	500	40	10000	2	2 A			t_{on}<1.2μs, t_f<1.2μs t_{stg}< 4 μs							370	ダーリントン
〃 4348	〃	〃	〃	100	100	5 A	25W (Tc=25°C)	150	1	100	10000	2	2 A			〃							370	〃
〃 4349	〃	〃	〃	100	100	8 A	30W (Tc=25°C)	150	1	100	10000	2	4 A			〃							370	〃
〃 4350	〃	〃	〃	100	100	10A	40W (Tc=25°C)	150	1	100	10000	2	5 A			〃							370	〃
〃 4351	〃	〃	〃	60±10	60±10	5 A	20W (Tc=25°C)	150	500	40	10000	2	2 A			〃							96	〃
〃 4352	〃	〃	〃	100	100	5 A	20W (Tc=25°C)	150	1	100	10000	2	2 A			〃							96	〃
〃 4353	〃	〃	〃	100	100	10A	25W (Tc=25°C)	150	1	100	10000	2	5 A			〃							96	〃
〃 4354	ローム	〃	Si. TP	400	400	2 A	15W (Tc=25°C)	150	10	400	25	5	100			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							165	
〃 4355	〃	〃	〃	100	80	4 A	25W (Tc=25°C)	150	10	100	270	4	1 A	12	−200					10 *	60	10	165	
〃 4356	三菱	RF. AF. PA	Si. E	60	60	2 A	900	150	0.2	50	150	4	100	2	−10					80 *	18	$C_c r_{bb'}$ 400ps	6	
〃 4357	〃	〃	〃	60	60	2 A	500	150	0.2	50	150	4	100	2	−10					80 *	18	$C_c r_{bb'}$ 400ps	336	
〃 4358	松下	PA	Si. P	35	25	300	2 W	150	100	35	100	10	50	10	−50					2500*	2.6		364	
〃 4359	〃	SW	Si. TP	900	800	3 A	80W (Tc=25°C)	150	50	900	10	5	800			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 4 μs							82	
〃 4360	三洋	〃	Si. EP	50	50	100	200	150	0.1	40	85	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_{BE}=10k±3kΩ)									176	
〃 4361	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	85	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_{BE}=10k±3kΩ)									92	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC4362	三洋	SW	Si. EP	50	50	100	200	150	0.1	40	55	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_{BE}=4.7k±1.4kΩ)									176	
〃 4363	〃	〃	〃	50	50	100	300	150	0.1	40	55	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=4.7k±1.4kΩ, R_{BE}=4.7k±1.4kΩ)									92	
〃 4364	〃	RF	〃	25	15	30	250	150	1	15	100	3	5	3	−5					3000*	0.75	$C_c r_{bb'}$ 2 ps	176	
〃 4365	〃	〃	〃	25	15	50	250	150	1	15	100	3	10	3	−10					3000*	1	$C_c r_{bb'}$ 2 ps	176	
〃 4366	日立	〃	Si. E	60	50	300	150	150	1	50	1400	6	100	6	−10					250*	5	$C_c r_{bb'}$ 180ps	176	
〃 4367	〃	〃	〃	30	20	100	600	150	1	10	100	10	10	10	−10					1000*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 10ps	251	
〃 4368	韓国電子	PA	Si. T	150	150	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	10	120	75	10	500	10	−500					4*	35		381	
〃 4369	〃	〃	Si. EP	30	30	3 A	15W (Tc=25°C)	150	1	20	70~240	2	500	2	−500					100*	35		381	
〃 4370	〃	〃	〃	160	160	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	160	70~240	5	100	10	−100					100*	25		381	
〃 4371	〃	SW	Si. T	500	400	5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	400	>12	5	3 A			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							381	
〃 4372	〃	RF	Si. EP	200	150	50	500	150	0.1	200	70~240	5	10	30	−10					120*	3.5		336	
〃 4373	〃	〃	〃	120	120	800	500	150	0.1	120	80~240	5	100	5	−100					120*	<30		336	
〃 4374	〃	〃	〃	80	80	400	500	150	0.1	80	70~240	2	50	10	−10					100*	10		336	
〃 4375	〃	AF	〃	30	30	1.5A	500	150	0.1	30	100~320	2	500	2	−500					120*	<40		336	
〃 4376	〃	〃	〃	35	30	800	500	150	0.1	35	100~320	1	100	5	−10					120*	13		336	
〃 4377	〃	RF	〃	30	10	2 A	500	150	0.1	30	140~600	1	500	1	−500					150*	27		336	
〃 4378	三洋	〃	〃	300	300	200	10W (Tc=25°C)	150	0.1	200	150	10	10	30	−10					70*	3.9	$C_c r_{bb'}$ 18ps	389	
〃 4379	松下	SW	Si. TP	500	400	15A	120W (Tc=25°C)	150	100	500	20	5	7 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.1μs t_{stg}< 2 μs							82	
〃 4380																								
〃 4381																								
〃 4382																								
〃 4383	富士電機	SW	Si. TP	200	180	8 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	80~300	4	1 A			t_{on}< 2 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 4 μs							202	
〃 4384																								
〃 4385																								
〃 4386																								
〃 4387																								
〃 4388																								
〃 4389																								
〃 4390																								
〃 4391	松下	AF	Si. EP	80	80	1 A	1 W (Tc=25°C)	150	0.1	40	200	2	100	10	−50					120*	10	30	259	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ic(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC4392																								
〃 4393																								
〃 4394																								
〃 4395																								
〃 4396																								
〃 4397																								
〃 4398																								
〃 4399																								
〃 4400																								
〃 4401																								
〃 4402																								
〃 4403																								
〃 4404																								
〃 4405																								
〃 4406																								
〃 4407																								
〃 4408																								
〃 4409																								
〃 4410	松下	RF	Si.EP	10	7	10	50	150			100	1	1	1	−1					4000*	0.4	$C_c r_{bb'}$ 33ps	412	
〃 4411																								
〃 4412																								
〃 4413																								
〃 4414																								
〃 4415																								
〃 4416																								
〃 4417	松下	RF	Si.EP	45	35	50	150	150	10	45	50	10	10	10	−10					500*	1.5	130	412	
〃 4418																								
〃 4419																								
〃 4420	松下	SW	Si.TP	900	800	3 A	70W (Tc=25°C)	150	50	900	10	5	800			t_{on}<0.7μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.5μs							82	
〃 4421	〃	〃	〃	500	400	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	500	20	5	1.5A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.1μs t_{stg}<2μs							364	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a=25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SD 11	日電	SW	Ge. A	25	20R	300	150	85	10	25	70	1	20	6	−1					2.5			84 A	
★	〃 12	松下	PA	Si. Me	75	75S	2.5A	60 W (Tc=25°C)	150	10mA	75	50	4	1 A										102	
★	〃 13	〃	〃	〃	35	35S	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	40mA	35	40	10	2.5A										109	
★	〃 14	〃	〃	〃	75	75S	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	45mA	75	30	4	10 A										109	
★	〃 15	サンケン	PA. SW	Si. DJ	60	40	6 A	80 W (Tc=25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	−500					2			102	
★	〃 16	〃	〃	〃	100	55	6 A	80 W (Tc=25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	−500					2			102	
★	〃 17	〃	〃	〃	150	70	6 A	80 W (Tc=25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	−500					2			102	
★	〃 18	〃	PA	〃	200	85	6 A	80 W (Tc=25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	−500					2			102	
★	〃 19	日電	〃	Ge. A	25	18R	300	150	85	12	12	31	1	20	6	−1					>1			84 A	2SB219 とコンプリ
★	〃 20	〃	〃	〃	25	18R	300	150	85	12	12	50	1	20	6	−1					>1			84 A	2SB220 とコンプリ
★	〃 21	〃	〃	〃	25	18R	300	150	85	12	12	72	1	20	6	−1					>1			84 A	2SB221 とコンプリ
★	〃 22	〃	〃	〃	25	18R	300	150	85	12	12	97	1	20	6	−1					>1			84 A	2SB222 とコンプリ
★	〃 23	〃	〃	〃	25	18R	300	150	85	12	12	150	1	20	6	−1					>1			84 A	2SB223 とコンプリ
	〃 24	三洋	〃	Si. Me	300	300R	100	6 W (Tc=70°C)	110	1.5	100	60	10	50	30	−20					25*	17		99	
★	〃 25	日電	〃	Ge. A	25	25R	100	110	75	14	12	70	1	50	6	−1					1			12 A	
★	〃 26	三菱	PA. SW	Si. EP	40	30	7 A	50 W (Tc=25°C)	175	100	30	10	4	5 A			h_{FE}=120 (4V, 1A)							102	
★	〃 26A	〃	〃	〃	60	40	7 A	50 W (Tc=25°C)	175	100	30	10	4	5 A			h_{FE}=120 (4V, 1A)							102	
★	〃 26B	〃	〃	〃	100	60	7 A	50 W (Tc=25°C)	175	100	30	10	4	5 A			h_{FE}=120 (4V, 1A)							102	
★	〃 26C	〃	〃	〃	150	80	7 A	50 W (Tc=25°C)	175	100	30	10	4	5 A			h_{FE}=120 (4V, 1A)							102	
★	〃 27	松下	PA	Ge. A	32	32S	500	280	90	10	0.5	95	0.5	300										12 A	
★	〃 28	ソニー	〃	Si. DJ	70	40	3 A	18 W (Tc=25°C)	150	20	30	100	1	100										100	
★	〃 29	〃	〃	〃	70	60	3 A	18 W (Tc=25°C)	150	20	30	100	1	100										100	
★	〃 30	三洋	〃	Ge. A	25		200	300	85	15	20	100	1.5	100	6	−1					1			63	2SB22 とコンプリ
★	〃 31	松下	〃	〃	25	25S	125	125	75	15	10	50	1	100				NF = 3dB						12 B	2SB172 とコンプリ
★	〃 32	〃	〃	〃	25	25S	125	125	75	15	10	90	1	100				NF = 3dB						12 B	2SB176 とコンプリ
★	〃 33	富士通	〃	〃	20	15R	50	150	85	14	12	70	1	50	6	−1	60	1780	3.8	17.3	2			12 A	2SB33 とコンプリ
★	〃 34	〃	〃	〃	20	15R	150	250	85	14	12	100	1	150	6	−1	60	1800	5	20	2			71 A	2SB34 とコンプリ
★	〃 35	松下	〃	〃	20	20S	60	83	75	10	10	72	1	18										4	
★	〃 36	〃	〃	〃	20	20S	60	83	75	10	10	150	1	37.5										4	
★	〃 37	富士通	〃	〃	30	20R	50	150	85	14	30	7	1	50	6	−1	60	1780	3.8	17.3	2			12 A	2SB37 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SD 38	富士通	PA	Ge. A	30	20R	150	250	85	16	30	75	1	150	6	−1	60	1800	5	20	2			71 A	2SB38とコンプリ
★	〃 39	三洋																							
★	〃 40	〃																							
★	〃 41	東芝	PA	Si. DJ	80	80	10 A	200 W (Tc=25°C)	150	200	50	60	5	1 A										102	
★	〃 42																								
★	〃 43	東芝	PA	Ge. A	25	25R	50	110	75	14	12	70	1	50	6	−1								12 A	2SB43とコンプリ
★	〃 43A	〃	〃	〃	45		150	110	75	14	12	70	1	50	6	−1								12 A	2SB43Aとコンプリ
★	〃 44	〃	AF	〃	25		50	80	75	14	12				6	−1	85	2500	5	30	>0.5	25		12 A	2SB44とコンプリ
★	〃 45	ソニー	PA	Si. Me	150	100	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5mA	50	40	10	1 A										102	
★	〃 46	〃	〃	〃	150	75	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5mA	50	40	10	1 A										102	
★	〃 47	〃	〃	〃	100	50	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5mA	15	40	10	1 A										102	
	〃 48	富士通	〃	Si. DJ	100	55	3 A	20 W (Tc=25°C)	175	15	30	50	4	750							1.5			83	
★	〃 49	ソニー	〃	〃	100	60	3 A	18 W (Tc=25°C)	150	20	30	50	3	1 A	10	−0.5A					2			100	
	〃 50	富士通 日立	〃	〃	100	55	6 A	50 W (Tc=25°C)	175	15	30	30	4	1.5A							1.5			102	
★	〃 51	ソニー	〃	Si. Me	100	50	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5mA	15	60	3	2 A	10	−0.5A					10			102	○
	〃 52	サンケン	PA. SW	Si. DJ	100	55	6 A	80 W (Tc=25°C)	175	10	40	20	4	3 A	12	−0.5A					2			102	
★	〃 53	富士通	〃	〃	90	50	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−0.5A					1.2			102	
★	〃 54	〃	〃	〃	100	50	10 A	150 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−0.5A					1.2			109	
★	〃 55	東芝	PA	〃	100	55	20 A	200 W (Tc=25°C)	150	10mA	50	24	5	10 A							1			102	
★	〃 56	ソニー	〃	〃	220	80	3 A	30 W (Tc=25°C)	150	50	50	50	1	100										100	
★	〃 57	三菱	PA. SW	〃	30	20	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	200	20	70	4	1 A										100	
★	〃 58	〃	〃	〃	60	40	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	40	40	70	4	1 A										100	
★	〃 59	〃	〃	〃	100	60	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	30	50	60	4	1 A										102	
★	〃 60	〃	〃	〃	150	75	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	30	50	60	4	1 A										102	
★	〃 61	ソニー	AF. PA. LN	Ge. A	30	25R	100	120	75	10	25	50	1	10	6	−1	−0.977*	28*	1.2*	0.29*	1	35		58	
★	〃 62	〃	SW	〃	30	25R	100	120	75	10	25	50	1	10	6	−1	−0.977*	28*	1.2*	0.25*	1	35		58	
★	〃 63	〃	PA	〃	25	20R	100	120	75	10	25	50	1	10	6	−1					1	35		58	
★	〃 64	〃	AF	〃	25	20R	100	120	75	15	25	100	1	10	6	−1	−0.987*	28*	1.2*	0.25*	1	35		58	
★	〃 65	〃	〃	〃	25	20R	100	120	75	15	25	50	1	10	6	−1	−0.977*	28*	1.2*	0.25*	1	35		58	
★	〃 66	〃	〃	〃	25	20R	100	120	75	15	25	25	1	10	6	−1	−0.958*	28*	1.2*	0.25*	0.8	35		58	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SD 67	三洋	PA	Si.TMe	120	120R	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5 mA	80	80	5	1 A							100 *			102	
★	〃 68	〃	〃	〃	75	75R	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	5 mA	60	80	5	1 A							100 *			102	
★	〃 69	ソニー	〃	〃	140	140	3 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	50	150	3	100										102	
★	〃 70	日電	PA	Si	40	25	2 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	24	80	2	1 A										150	
★	〃 71	〃	〃	〃	100	60	2 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	40	80	2	0.5 A										150	
★	〃 72	三洋	〃	Ge.A	25	25R	600	720 (Tc=25°C)	85	50	20	150	1.5	200										12 A	2SB405 とコンプリ
	〃 73	日電	〃	Si.EMe	100	60	5 A	60 W (Tc=25°C)	175	5mA	100	70	10	1 A	10	−300					20 *			102	2SB506 とコンプリ
	〃 74	〃	〃	〃	150	90	5 A	60 W (Tc=25°C)	175	5mA	150	70	10	1 A	10	−300					20 *			102	2SB506 とコンプリ
★	〃 75	日立	AF	Ge.A	25		100	150	85	14	25				6	−1	40	1260	3	15.8	4			12 A	2SB75 とコンプリ
★	〃 75A	〃	PA	〃	45	45S	100	150	85	25	45				6	−1	40	1260	3	15.8	4			12 A	2SB75A とコンプリ
★	〃 76																								
★	〃 77	日立	PA	Ge.A	25		100	150	85	14	25	85	1.5	50	6	−1	55	1680	3.1	16.3	3.5			12 A	2SB77 とコンプリ
★	〃 77A	〃	〃	〃	45	45S	100	150	85	25	45	85	1.5	50	6	−1	55	1680	3.1	16.3	3.5			12 A	2SB77A とコンプリ
	〃 78	日電	PA. SW	Si.E	100	60	2 A	1 W	175	1	60	80	2	500	10	−50					50 *			84B	2SB504 とコンプリ ○
	〃 79	〃	〃	〃	100	60	2 A	15 W (Tc=25°C)	175	1	60	80	2	500	10	−50					50 *			97B	2SB505 とコンプリ
★	〃 80	サンケン	PA. SW	Si.DJ	30	20	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	200	20	60	4	1 A	10	−200					3			102	
★	〃 81	〃	〃	〃	60	40	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	50	40	60	4	1 A	10	−200					3			102	
★	〃 82	〃	〃	〃	100	60	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	30	50	60	4	1 A	10	−200					3			102	
★	〃 83	〃	〃	〃	150	75	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	30	50	60	4	1 A	10	−200					3			102	
★	〃 84	〃	〃	〃	200	85	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	30	50	60	4	1 A	10	−200					3			102	
★	〃 85																								
★	〃 86																								
★	〃 87																								
★	〃 88	ソニー	PA	Si.TMe	100	55	5 A	80 W (Tc=25°C)	150	100	50	80	3	2 A										102	
★	〃 89																								
★	〃 90	サンケン	PA. SW	Si.DJ	30	20	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	200	20	40	4	1 A	10	−200					3.5			100	
★	〃 91	〃	〃	〃	60	40	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	50	40	40	4	1 A	10	−200					3.5			100	
★	〃 92	〃	〃	〃	100	55	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	30	50	40	4	1 A	10	−200					3.5			100	
★	〃 93	〃	〃	〃	150	70	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	30	50	40	4	1 A	10	−200					3.5			100	
★	〃 94	〃	〃	〃	200	80	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	30	50	40	4	1 A	10	−200					3.5			100	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SD 95	サンケン																								
★	〃 96	日立	PA	Ge. A	25	18R	250	300 (Tc<55°C)	85	14	25	90	1.5	50	6	−1					4			12 A	2SB496 とコンプリ
★	〃 97																									
★	〃 98																									
★	〃 99																									
★	〃 100	東芝	PA	Ge. A	32	32R	400	250	85	40	12	75	1	150										77	2SB200 とコンプリ
★	〃 100A	〃	〃	〃	45		400	250	85	40	12	75	1	150										77	
★	〃 101	〃	〃	〃	80	80R	600	250	75	50	12	70	1	150										77	
★	〃 102	〃	〃	Si. DJ	110	80	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	50	30~300	5	500	10	−500					1 *	150		99	
★	〃 103	東芝	PA. SW	〃	80	50	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	100	50	30~300	5	500	10	−500					1 *	150		99	
★	〃 104	〃	PA	Ge. A	20	20R	400	150	75	14	12	90	0.5	100										12 A	2SB364 とコンプリ
★	〃 105	〃	〃	〃	20	20R	400	150	75	14	12	60	0.5	100										12 A	2SB365 とコンプリ
★	〃 106	〃																							
★	〃 107	東芝	PA	Si. TP	80	60	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	20	50	4000	5	1 A	10	−500					30 *			102	
★	〃 108	〃	〃	〃	80	40	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	2	50	4000	5	1 A										102	ダーリントン接続
★	〃 109	〃																							
★	〃 110	東芝	PA	Si. DJ	130	110	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	0.5 mA	50	30~300	5	1 A	10	−1A					2 *	200		102	
★	〃 111	〃	〃	〃	100	80	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	0.5 mA	50	30~300	5	1 A	10	−1A					2 *	200		102	
★	〃 112																								
★	〃 113	東芝	PA	Si. DJ	100	80	30 A	200 W (Tc=25°C)	150	2 mA	50	30~300	5	1 A		t_{on} = 3 μs, t_f = 5 μs t_{stg} = 5 μs					1.5 *	400		102	
★	〃 114	〃	〃	〃	70	50	30 A	200 W (Tc=25°C)	150	2 mA	50	30~300	5	1 A		t_{on} = 3 μs, t_f = 5 μs t_{stg} = 5 μs					1.5 *	400		102	
★	〃 115	〃																							
★	〃 116	富士通	PA	Si. TMe	100	40	7 A	75 W (Tc=25°C)	175	15	30	100	4	1 A										102	
★	〃 117	〃	〃	〃	150	80	7 A	75 W (Tc=25°C)	175	15	30	100	4	1 A										102	
★	〃 118	東芝	〃	Si. DJ	130	110	7 A	100 W (Tc=25°C)	150	50	50	30~200	5	1 A	10	−500					2 *	200		102	
★	〃 119	〃	〃	〃	100	80	7 A	100 W (Tc=25°C)	150	50	50	30~200	5	1 A	10	−500					2 *	200		102	
	〃 120	日立	SW	〃	60	40	1.5A	4 W (Tc=25°C)	175	10	30	60	4	200	12	−50		t_{on} = 0.75μs, t_f = 0.6μs t_{stg} = 4.1μs			1.1			84B	
	〃 121	〃	〃	〃	100	55	1.5A	4 W (Tc=25°C)	175	10	30	60	4	200	12	−50		t_{on} = 0.75μs, t_f = 0.6μs t_{stg} = 4.1μs			1.1			84B	
★	〃 122	〃	〃	〃	60	40	3 A	15 W (Tc=25°C)	175	15	30	40	4	750	12	−50					>0.6			83	
★	〃 123	〃	〃	〃	100	55	3 A	15 W (Tc=25°C)	175	15	30	40	4	750	12	−50					>0.6			83	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} (μA)	最大値 V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb} (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SD124	日立	SW	Si. DJ	60	40	6 A	60 W (Tc=25°C)	175	25	30	30	4	1.5A	12	−50		t_{on}=1.6μs, t_f=5μs t_{stg}=2.2μs			>0.5			102	
	〃 124A	〃	〃	〃	75	50	7 A	60 W (Tc=25°C)	175	25	30	40	4	1.5A	4	−1A		t_{on}=1.6μs, t_f=5μs t_{stg}=2.2μs			1			102	
★	〃 125	〃	〃	〃	100	55	6 A	60 W (Tc=25°C)	175	25	30	40	4	1.5A	12	−50					>0.5			102	
★	〃 125A	〃	〃	〃	100	75	7 A	60 W (Tc=25°C)	175	25	30	40	4	1.5A	4	−1A		t_{on}=1.6μs, t_f=5.5μs t_{stg}=2.2μs			1			102	
★	〃 126	〃	PA. SW	Si. DJ	150	100	7 A	60 W (Tc=25°C)	175	25	30	10	4	6 A	4	−1A		t_{on}=1.6μs, t_{off}=6μs t_{stg}=2.2μs			1			102	
★	〃 127	ソニー	PA	Ge. A	23	20R	500	250	85	15	15	82	1	20	6	−1		28*	2.5*	0.4*	4			12 A	
★	〃 127A	〃	〃	〃	23	20R	500	250	85	15	15	82	1	20	6	−1		28*	2.5*	0.4*	4			12 A	
★	〃 128	〃	〃	〃	32	30R	500	250	85	15	15	82	1	20	6	−1		28*	2.5*	0.4*	4			12 A	
★	〃 128A	〃	〃	〃	32	30R	500	250	85	15	15	82	1	20	6	−1		28*	2.5*	0.4*	4			12 A	
★	〃 129	東芝	〃	Si. DJ	90	80	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	1 mA	50	30~200	5	500	10	−500					1*	250		99	
★	〃 130	〃	〃	〃	60	50	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	1 mA	50	30~200	5	500	10	−500					1*	250		99	
★	〃 131	〃	〃	Si. T	100	80	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	50	60	5	1 A										102	
	〃 132	日電	〃	Si. EMe	100	65	20 A	150 W (Tc=25°C)	175	5 mA	65	40	5	20 A										106	
★	〃 133																								
★	〃 134	ソニー	SW	Ge. G	60	60R	5	30	65	8	15	40	5	3								2		18	
★	〃 135																								
★	〃 136	富士通	PA	Si. T	200	200	100	4 W (Tc=25°C)	150	10	150	80	10	50										98 A	
★	〃 137	〃	〃	〃	300	300	100	4 W (Tc=25°C)	150	10	150	80	10	50										98 A	
★	〃 138	〃	PA. SW	〃	200	200	1 A	30 W (Tc=25°C)	175	20	150	75	10	0.5A										101	
★	〃 139	〃	〃	〃	300	300	1 A	30 W (Tc=25°C)	175	20	150	75	10	0.5A										101	
★	〃 140																								
★	〃 141	日電	PA	Si. E	20	12	3 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	12	80	2	1 A										150	
★	〃 142	〃	〃	〃	40	20	3 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	20	80	2	1 A										150	
★	〃 143	〃	〃	〃	80	40	2 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	40	80	2	0.5A										150	
★	〃 144	〃	〃	〃	100	50	2 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	50	80	2	0.5A										150	
★	〃 145																								
	〃 146	富士通	PA. SW	Si. DJ	40	35	1 A	20 W (Tc=25°C)	175	20	30	60	4	500	6	−0.5A					1.4			101	
	〃 147	〃	〃	〃	60	50	1 A	20 W (Tc=25°C)	175	20	30	50	4	500	6	−0.5A					1.4			101	
	〃 148	〃	SW	〃	70	70X	2 A	20 W (Tc=25°C)	175	20	30	35	4	2 A	4	−100					1.2*			101	
	〃 149	〃	PA. SW	〃	70	70X	1 A	800	175	20	30	40	4	1 A	4	−100					1.2			84 B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SD150	日電	PA	Si.E	50	40	1 A	15 W (Tc=25°C)	150	100	40	80	2	1 A										150	2SA613 とコンプリ
	〃 151	〃	SW	Si.EMe	100	60	10 A	120 W (Tc=25°C)	175	1 mA	60	35	10	10 A										102	
★	〃 152	〃	PA	Si.E	150	70	1 A	15 W (Tc=25°C)	175	100	70	70	2	0.5 A										150	
★	〃 153	〃	PA.SW	Si.TMe	250	200	10 A	120 W (Tc=25°C)	175	1 mA	200	70	5	1 A										200	
★	〃 154	〃	PA	Si.EMe	80	60	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	1 mA	60	65	2	2 A										150	
★	〃 155	〃	〃	〃	80	60	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	1 mA	60	65	2	2 A										134	2SA616 とコンプリ
	〃 156	富士通	〃	Si.T	200	200	100	4 W (Tc=70°C)	150	10	150	80	10	50	30	−10					20*	8	25*	99	
	〃 157	〃	〃	〃	300	300	100	4 W (Tc=70°C)	150	10	150	80	10	50	30	−10					20*	8	25*	99	
	〃 158	〃	PA.SW	〃	200	200	1 A	30 W (Tc=25°C)	175	20	150	75	10	0.5 A	10	−100					15*			99	
	〃 159	〃	〃	〃	300	300	1 A	30 W (Tc=25°C)	175	20	150	75	10	0.5 A	10	−100					15*			99	
	〃 160	〃	〃	Si.DJ	100	55	1.5 A	25 W (Tc=25°C)	175	10	30	50	10	750										83	
	〃 161	〃	PA	〃	120	70	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	30	30	4	5 A	6	−500					1			102	
★	〃 162	〃	AF.PA	Ge.A	20	15R	30	65	85	12	12	80	1.5	30	6	−1	60	2000	4	17	3			4	2SB262 とコンプリ
★	〃 163	サンケン	PA.SW	Si.DJ	60	40	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	50	40	30	4	5 A	12	−500					2			102	
★	〃 164	〃	〃	〃	100	55	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	50	40	30	4	5 A	12	−500					2			102	
★	〃 165	〃	〃	〃	150	70	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	50	40	30	4	5 A	12	−500					2			102	
★	〃 166	〃	〃	〃	200	85	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	50	40	30	4	5 A	12	−500					2			102	
★	〃 167	富士通	AF.PA	Ge.A	20	20S	500	200	85	20	12	120	1	150										12 A	
	〃 168	〃	SW	Si.DJ	80	70	10 A	50 W (Tc=25°C)	175	30	30	2500	4	5 A			$V_{CE(sat)}$<3.0 V (I_C=5 A, I_B=25 mA)			$V_{BE(sat)}$<3.5 V (I_C=5 A, I_B=25 mA)				102	ダーリントン接続
★	〃 169																								
★	〃 170	日立	PA	Ge.A	25	18	500	200	85	20	12	150	1	150										12A	2SB370 とコンプリ ○
★	〃 171	ソニー	〃	Si.TMe	450	150	3.5 A	125 W (Tc=25°C)	150	100	50	70	3	1 A										102	
	〃 172	富士通	PA.SW	Si.DJ	60	40	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−500					1.2			102	
	〃 173	〃	〃	〃	100	60	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−500					1.2			102	
	〃 174	〃	PA	〃	60	40	5 A	50 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−500					1.2			102	
	〃 175	〃	PA.SW	〃	100	60	5 A	50 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−500					1.2			102	
	〃 176	〃	〃	〃	90	50	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−500					1.2			102	
	〃 177	〃	〃	〃	120	70	10 A	100 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A	6	−500					1.2			102	
★	〃 178	松下	PA	Ge.A	20	20S	300	225	75	27	12	90	0.5	300										17	2SB178 とコンプリ
★	〃 178A	〃	〃	〃	40	40S	300	225	75	27	12	90	0.5	300										17	2SB178A とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SD179	日電	PA. SW	Si. TMe	300	300	40 A	580 W (Tc=25°C)	175	1 mA	300	30	5	20 A										201	
★	〃 180	〃	PA	Si. EMe	80	70	6 A	60 W (Tc=25°C)	150	100	70	60	2	3 A	10	−200					10 *	150		102	2SA626 とコンプリ
★	〃 181	〃	PA. SW	Si. TMe	150	100	15 A	100 W (Tc=25°C)	175	1 mA	100	60	5	5 A										102	
★	〃 182	富士通	PA	Si. DJ	40	30	1 A	10 W (Tc=25°C)	175	15	30	35	4	750	6	−500					1.5			83	
	〃 183	〃	〃	〃	100	55	1 A	10 W (Tc=25°C)	175	15	30	35	4	750	6	−500					1.5			83	
	〃 184	〃	SW	〃	60	40	1.5A	25 W (Tc=25°C)	175	10	30	35	4	750	6	−500					1.5			83	
	〃 185	〃	〃	〃	100	55	1.5A	25 W (Tc=25°C)	175	10	30	35	4	750	6	−500					1.5			83	
★	〃 186	三洋	PA	Ge. A	25		150	200	85	15	20				6	−1	120	2500	10	35	1	60		12 A	2SB186 とコンプリ
★	〃 187	〃	〃	〃	25		150	200	85	15	20	100	1.5	30	6	−1					1			12 A	2SB187 とコンプリ
★	〃 188	日電	PA	Si. EMe	100	80	7 A	60 W (Tc=25°C)	150	100	80	60	2	3 A	10	−200					10 *	150		102	2SA627 とコンプリ
★	〃 189	松下	PA	Si. TMe	80	80	5 A	50 W (Tc=75°C)	150	5 mA	80	50	4	4 A	10	−500					12 *			102	
★	〃 189A	〃	〃	〃	100	100	5 A	50 W (Tc=75°C)	150	5 mA	100	50	4	4 A	10	−500					12 *			102	
★	〃 190	日立	〃	Si. T	300	300R	100	4 W (Tc=25°C)	150	100	300	60	10	50										98A	
★	〃 191	東芝	〃	Ge. A	30	25R	150	150	75	14	12	80	1	50										84 A	
★	〃 192	〃	〃	〃	30	25R	150	150	75	14	12	80	1	50										84 A	
★	〃 193	〃	SW	〃	35	35R	400	250	85	35	12	100	1	150										84 A	
★	〃 194	〃	PA	〃	32	32R	400	250	85	40	12	75	1	150										84 A	
★	〃 195	富士通	SW	〃	20		50	150	85	14	12	70	1	50	6	−1					>2.5			12 A	
★	〃 196	〃	〃	Si. DJ	100		10 A	125 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A										109	
★	〃 196A	〃	PA. SW	〃	100	50	10 A	150 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A										109	
★	〃 197	〃	SW	〃	130		10 A	125 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A										109	
★	〃 197A	〃	PA. SW	〃	130	70	10 A	150 W (Tc=25°C)	175	20	30	25	4	5 A										109	
	〃 198	松下	PA	Si. TMe	300	300R	1 A	25 W (Tc=75°C)	150	5 mA	300	120	5	100	10	−100					45 *			102	
★	〃 199	〃	〃	〃	800	700R	500	25 W (Tc=75°C)	150	1 mA	800	55	10	200	10	−100					7 *			102	
★	〃 200	〃	SW	〃	1500	1500S	2.5A	15 W (Tc=90°C)	130	1 mA	1500	2.5	5	2 A			t_f=0.7μs							102	水平偏向用 ○
★	〃 201	サンケン	PA. SW	Si. DJ	90	60	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	50	40	40	4	3 A	12	−500					8			102	
★	〃 202	〃	〃	〃	110	80	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	50	40	40	4	3 A	12	−500					8			102	
★	〃 203	〃	〃	〃	130	100	6 A	50 W (Tc=25°C)	150	50	40	40	4	3 A	12	−500					8			102	
★	〃 204	日電	PA	Si. E	60	30	700	6 W (Tc=25°C)	150	3	50	80	2	300										84B	
★	〃 205	〃	〃	〃	60	30	700	1 W	150	3	30	80	2	300										97 B	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考	
★	2SD206	新電元	PA. SW	Si. DJ	50	30	10A	150W (Tc=25°C)	150	50mA	30	20	5	5 A	10	−1A	50	7	70	10mS	f_{ae} 18kHz			102		○
★	〃 207	〃	〃	〃	100	60	10A	150W (Tc=25°C)	150	50mA	30	20	5	5 A	10	−1A	50	7	70	10mS	f_{ae} 18kHz			102		○
★	〃 208	〃	〃	〃	150	90	10A	150W (Tc=25°C)	150	50mA	30	20	5	5 A	10	−1A	50	7	70	10mS	f_{ae} 18kHz			102		○
★	〃 209	〃																								
★	〃 210	〃																								
★	〃 211	サンケン	PA. SW	Si. DJ	60	40	10A	100W (Tc=25°C)	150	50	40	30	4	5 A	12	−500					8			102		
★	〃 212	〃	〃	〃	90	60	1 A	100W (Tc=25°C)	150	50	40	30	4	5 A	12	−500					8			102		
★	〃 213	〃	〃	〃	110	80	10A	100W (Tc=25°C)	150	50	40	30	4	5 A	12	−500					8			102		
★	〃 214	〃	〃	〃	130	100	10A	100W (Tc=25°C)	150	50	40	30	4	5 A	12	−500					8			102		
	〃 215	富士通	PA	〃	40	35	1 A	800	175	20	30	70	4	500	4	−100					1.2			84B		
	〃 216	〃	〃	〃	60	50	1 A	800	175	20	30	70	4	500	4	−100					1.2			84B		
★	〃 217	日電	〃	Si.EMe	120	80	7A	60W (Tc=25℃)	150	500	80	60	5	4 A	10	−200					10 *			102	2SA648 とコンプリ	
★	〃 218	〃	〃	〃	150	100	7A	60W (Tc=25℃)	150	500	80	60	5	4A	10	−200					10 *			102	2SA649 とコンプリ	
★	〃 219	サンケン	PA. SW	Si. DJ	40	30	1 A	500	150	1	20	80	4	200	5	−100					8			84B		
★	〃 220	〃	〃	〃	80	50	1 A	500	150	1	20	80	4	200	5	−100					8			84B		
★	〃 221	〃	〃	〃	110	80	1 A	500	150	1	20	80	4	200	5	−100					8			84B		
★	〃 222	〃	〃	〃	40	30	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	500	5	−100					8			97B		
★	〃 223	〃	〃	〃	80	50	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	20	60	4	500	5	−100					8			97B		
★	〃 224	〃	〃	〃	110	80	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	20	40	4	500	5	−100					8			97B		
★	〃 225																									
★	〃 226	松下	PA	Si. DJ	40	40	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	50	3	1 A	10	−200					f_{ae} 25kHz			99		○
★	〃 227	日電	〃	Si. E	30	15	300	250	125	0.1	15	150	1	50										138	2SA642 とコンプリ	
★	〃 228	〃	〃	〃	30	15	300	400	125	0.1	15	120	1	300	10	−10	200							44		
★	〃 229	〃																								
★	〃 230	〃																								
	〃 231	富士通	SW. AF	Si.TMe	50	40	30A	125W (Tc=25°C)	175	100	30	25	4	10A										102		
	〃 232	〃	〃	〃	120	100	30A	125W (Tc=25°C)	175	1 mA	50	25	4	10A										102		○
★	〃 233	日電																								
	〃 234	東芝	PA	Si.T	60	50	3 A	25W (Tc=25°C)	150	100	20	40~240	5	500	10	−500					3 *	90		268	2SB434 とコンプリ	
	〃 235	〃	〃	〃	50	40	3 A	25W (Tc=25°C)	150	100	20	40~240	5	500	10	−500					3 *	90		268	2SB435 とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SD236	サンケン	PA. SW	Si. DJ	40	30	1 A	10 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	500	5	−100					8			99	
★	〃 237	〃	〃	〃	80	50	1 A	10 W (Tc=25°C)	150	10	20	60	4	500	5	−100					8			99	
★	〃 238	〃	〃	〃	110	80	1 A	10 W (Tc=25°C)	150	10	20	40	4	500	5	−100					8			99	
★	〃 239	〃																							
★	〃 240	〃																							
★	〃 241	〃	PA. SW	Si. DJ	60	40	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	−200					8			100	
★	〃 242	〃	〃	〃	90	60	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	−200					8			100	
★	〃 243	〃	〃	〃	110	80	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	60	4	1 A	10	−200					8			100	
★	〃 244	〃	〃	〃	130	100	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	60	4	1 A	10	−200					8			100	
★	〃 245	〃																							
★	〃 246	松下	PA. SW	Si. Me	1500	1500S	4.5 A	16 W (Tc=90°C)	115	1mA	1500	> 2	10	4 A			$V_{CE(sat)}$ < 10 V (4.5A, 2 A)			$V_{BE(sat)}$ < 1.6 V (4.5A. 2 A)				102	水平偏向用
	〃 247	芝電	PA	Si. TMe	80	60	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	30	60	5	1 A										102	
★	〃 248	東芝																							
	〃 249	富士通	PA. SW	Si. DJ	50	40	30 A	125 W (Tc=25°C)	175	100	30	25	4	10 A	4	−1A					0.8 *			102	
	〃 250	〃	〃	〃	100	100	30 A	125 W (Tc=25°C)	175	100	50	25	4	10 A	4	−1A					0.6 *			102	
	〃 251	〃	SW. AF	Si. TMe	200	200	2 A	30 W (Tc=25°C)	175	5	150	100	10	500										99	
★	〃 252																								
★	〃 253																								
★	〃 254	日電	PA	Si. EMe	70	50	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	1 mA	60	65	2	2 A										150	
★	〃 255	〃	〃	〃	70	50	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	1 mA	60	65	2	2 A										134	2SA615 とコンプリ
★	〃 256	サンケン	PA. SW	Si. DJ	60	40	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	−200					8			99	
★	〃 257	〃	〃	〃	90	60	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	−200					8			99	
★	〃 258	〃	〃	〃	110	80	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	−200					8			99	
★	〃 259	〃	〃	〃	130	100	4 A	25 W (Tc=25°C)	150	10	20	80	4	1 A	10	−200					8			99	
	〃 260	芝電	PA	Si. TMe	100	80	5 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	30	60	4	1 A										102	
★	〃 261	日電	〃	Si. E	40	20	500	500	125	0.2	25	140	1	100	6	−10					120 *			44	2SA643 とコンプリ
★	〃 262	ソニー	〃	Si. TMe	300	140	12 A	125 W (Tc=25°C)	150	100	50	50	3	5 A										102	
★	〃 263	オリジン																							
★	〃 264	〃																							
	〃 265	〃	PA. SW	Si. T	800	400	6 A	100 W (Tc=25°C)	150	2mA	800	20	5	3 A										102	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SD266	オリジン	PA. SW	Si. T	800	400	6 A	100 W (Tc=25°C)	150	2mA	800	40	5	3 A										102	
★	〃 267	〃																							
★	〃 268	〃																							
★	〃 269	〃																							
★	〃 270	〃																							
	〃 271	〃	PA	Si. T	800	400	2 A	30 W (Tc=25°C)	150	2mA	800	20	5	1 A	12	−500					$f_{\alpha e}$ 150kHz			100	
	〃 272	〃	〃	〃	800	400	2 A	30 W (Tc=25°C)	150	2mA	800	40	5	1 A	12	−500					$f_{\alpha e}$ 150kHz			100	
	〃 273	〃	PA. SW	〃	800	400	5 A	80 W (Tc=25°C)	150	2mA	800	20	5	2 A	12	−1 A					$f_{\alpha e}$ 150kHz			102	
	〃 274	〃	〃	〃	800	400	5 A	80 W (Tc=25°C)	150	2mA	800	40	5	2 A	12	−1 A					$f_{\alpha e}$ 150kHz			102	
★	〃 275	〃																							
★	〃 276	〃																							
★	〃 277	〃																							
★	〃 278	〃																							
★	〃 279	〃																							
★	〃 280	〃																							
★	〃 281	〃																							
★	〃 282	〃																							
★	〃 283	日電	PA. SW	Si. E	120	40	5 A	25 W (Tc=25°C)	150	200	40	55	1	5 A										134	
★	〃 284	〃	〃	〃	120	40	5 A	25 W (Tc=25°C)	150	200	40	80	5	1 A	10	−100					20 *			134	2SB550 とコンプリ
★	〃 285	〃	〃	〃	100	40	5 A	25 W (Tc=25°C)	150	200	40	40	1	5 A										134	
★	〃 286	〃	PA	Si.TMe	180	100	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	300	100	75	5	2 A										102	
★	〃 287	〃	〃	〃	200	120	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	300	100	75	5	2 A										102	2SB539 とコンプリ ○
	〃 288	〃	〃	Si. T	80	60	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	10	60	100	5	500	5	−100					35 *	55		268	
	〃 289	〃	〃	〃	80	60	3 A	20 W (Tc=25°C)	150	10	60	100	5	500	5	−100					35 *	55		267	
★	〃 290	ソニー	PA. SW	Si. TMe	80	80	5 A	10 W (Tc=25°C)	120	100	150	100	3	2 A										153	
★	〃 291	〃	RF. PA	Si. DJ	70	40	3 A	18 W (Tc=25°C)	150	20	30	100	1	100	10	−500					4 *	250		153	
★	〃 292	〃	PA	〃	70	55	3 A	18 W (Tc=25°C)	150	20	30	100	1	100	10	−500					4 *	250		153	
★	〃 293	オリジン	〃	Si.T	800	400	10A	125W (Tc=25°C)	150	3mA	800	20	5	5 A										102	
★	〃 294	〃	〃	〃	800	400	10A	125W (Tc=25°C)	150	3mA	800	40	5	5 A										102	
	〃 295	〃	PA. SW	Si. T	800	400	30 A	200 W (Tc=25°C)	150	5 mA	800	20	5	10 A	12	−2.5A					$f_{\alpha e}$ 150kHz			266	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SD296	オリジン	PA. SW	Si. T	800	400	30 A	200 W (Tc=25°C)	150	5 mA	800	40	5	10 A	12	−2.5A					$f_{\alpha e}$ 150kHz			266	
	〃 297	日電	〃	Si. E	150	80	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	500	80	120	2	2 A	10	−100					40 *			134	2SB563 とコンプリ
★	〃 298	三洋																							
★	〃 299	松下	PA. SW	Si. Me	1500	1500S	5 A	16 W (Tc=90°C)	115	1mA	1500	> 2	5	4 A			$V_{CE(sat)}$ < 10 V, (4.5A, 2A)	$V_{BE(sat)}$ < 1.6 V (4.5A, 2A)						102	
★	〃 300	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	16 W (Tc=90°C)	115	1mA	1500	> 3	10	2.5 A			$V_{CE(sat)}$ < 10 V, (2.5A, 0.85A)	$V_{BE(sat)}$ < 1.6 V (2.5A, 0.85A)						102	水平偏向用
	〃 301	富士通	SW	Si. DJ	80	70	10 A	50 W (Tc=25°C)	175	30	30	2500	4	5 A			t_d < 11 μs, t_r < 53 μs, t_{stg} < 16 μs							102	ダーリントン接続
★	〃 302	オリジン																							
★	〃 303	〃																							
★	〃 304	〃																							
★	〃 305	〃																							
★	〃 306	〃																							
★	〃 307	〃																							
★	〃 308	〃																							
★	〃 309	〃																							
	〃 310	〃	PA. SW	Si. T	800	400	15 A	150 W (Tc=25°C)	150	3mA	800	20	5	7.5 A	12	−2 A					$f_{\alpha e}$ 150kHz			102	
	〃 311	〃	〃	〃	800	400	15 A	150 W (Tc=25°C)	150	3mA	800	40	5	7.5 A	12	−2 A					$f_{\alpha e}$ 150kHz			102	
★	〃 312	松下	PA	Si. TMe	800	600R	500	25 W (Tc=100°C)	150	1 mA	800	60	10	600	10	−100					5 *			102	
	〃 313	三洋	〃	Si. T	60	60	3 A	30 W (Tc=25°C)	150	100	20	40～320	2	1 A	5	−500					8 *	65		268	
	〃 314	〃	〃	〃	60	60	3 A	30 W (Tc=25°C)	150	100	20	40～320	2	1 A	5	−500					8 *	65		267	
★	〃 315	〃	〃	〃	60	60	4 A	35 W (Tc=25°C)	150	100	20	40～320	2	1 A	5	−500					8 *			99	2SB509 とコンプリ
★	〃 316	ソニー	〃	Si. TMe	80	80	7 A	80 W (Tc=25°C)	150	100	50	70	2	3 A	10	−500					12 *	260		102	
★	〃 317	松下	PA	Si. T	60	60	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	30	20	60	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$ = 25 kHz			268	○
★	〃 318	〃	〃	〃	60	60	3 A	25 W (Tc=25°C)	150	30	20	60	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$ = 25 kHz			267	○
★	〃 319	〃	〃	Si. DJ	110	80	10 A	100 W (Tc=25°C)	150	30	40	35	4	5 A	10	−500					1 *			102	
★	〃 320	三洋	PA. SW	Si. T	300	230	2 A	50 W (Tc=25°C)	150	100	100		15	1 A										102	
★	〃 321	松下	〃	Si. TMe	250	250S	6 A	60 W (Tc=75°C)	150	2 mA	250	40	5	5 A			t_f < 1 μs							102	
★	〃 322	日電	PA	〃	120	80	7 A	80 W (Tc=25°C)	150	300	120	60	5	4 A										102	
★	〃 323	〃	〃	〃	150	100	7 A	80 W (Tc=25°C)	150	300	150	60	5	4 A										102	
★	〃 324	松下	〃	〃	300	300R	100	10 W (Tc=70°C)	150	100	300	80	10	50										153	
	〃 325	三洋	〃	Si. T	35	35	1.5A	10 W (Tc=25°C)	150	100	20	40～320	2	1 A	5	−500					8 *			268	2SB511 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SD326	ソニー	PA. SW	Si.TMe	330	220	1 A	23W (Tc=25℃)	150	15	100	80	5	100							6.5*			100		
★	〃 327	日電	PA	Si.E	40	20	500	250	125	0.2	25	140	1	100										138	2SA723 とコンプリ	
★	〃 328	〃	PA. SW	〃	100	60	1 A	800	150	1	60	100	2	200	10	−50					50*			84B	2SB510 とコンプリ	
	〃 329	富士通	SW	Si.DJ	70	70R	1 A	800	175	20	30	40	4	1 A										84C		
	〃 330	三洋	PA	Si.T	50	50	2 A	20W (Tc=25℃)	150	100	20	40～320	2	1 A	5	−200					8*			268	2SB514 とコンプリ	
★	〃 331	〃	〃	〃	50	50	2 A	20W (Tc=25℃)	150	100	20	40～320	2	1 A	5	−200					8*			267	2SB515 とコンプリ	
★	〃 332	〃	〃	Si.DJ	130	100	7 A	65W (Tc=25℃)	150	1mA	50	40～200	5	1 A										102		
★	〃 333	〃																								
★	〃 334	松下	PA	Si.DJ	110	80	6 A	75W (Tc=25℃)	150	1mA	110	100	4	1 A	10	−500					f_{ae} 25kHz			102		○
★	〃 335	日電	〃	Si.EMe	80	60	3 A	30W (Tc=25℃)	150	300	60	80	5	2 A										102		
★	〃 336	〃	〃	Si.E	40	20	500	750	135	0.2	25	140	1	100										45	2SA707 とコンプリ	
★	〃 337	ソニー																								
★	〃 338	〃	PA	Si.EMe	90	90	7 A	70W (Tc=25℃)	150	100	50	50	2	3 A										102	2SB518 とコンプリ	
★	〃 339	〃	〃	〃	90	90	10 A	80W (Tc=25℃)	150	100	50	50	2	4 A	2	−4A					5*			102	2SB519 とコンプリ	
★	〃 340	〃	〃	〃	110	110	12 A	100W (Tc=25℃)	150	100	50	50	2	5 A	2	−5A					>3*			102	2SB520 とコンプリ	
	〃 341	日立	PA. SW	Si.DJ	100	60	15 A	115W (Tc=25℃)	200	5mA	100	20～70	4	4 A	4	−1 A	>15				>0.8*			102		
★	〃 342	ソニー	PA	〃	70	40	3 A	35W (Tc=25℃)	150	100	30	100	1	100										268		
★	〃 343	〃	〃	〃	70	40	3 A	35W (Tc=25℃)	150	100	30	100	1	100										267		
★	〃 344	〃	〃	〃	70	55	3 A	35W (Tc=25℃)	150	100	30	100	1	100										268		
★	〃 345	〃	〃	〃	70	55	3 A	35W (Tc=25℃)	150	100	30	100	1	100										267		
★	〃 346	〃	〃	Si.EMe	60	60	5 A	25W (Tc=25℃)	150	100	50	50	2	2.5A										268		
★	〃 347	〃	〃	〃	60	60	5 A	25W (Tc=25℃)	150	100	50	50	2	2.5A										267		
★	〃 348	三洋	SW	Si.TMe	1500	400	7 A	50W (Tc=25℃)	150	100	1000	>4.5	5	5 A			t_f<1μs							102	水平偏向用	
	〃 349	日電	AF	Si.E	30	25	50	150	125	0.1	25	500	3	0.5	3	−1		14k	5.8	23				176		
★	〃 350	松下	SW	Si.TMe	1500	700	5 A	35W (Tc=90℃)	130	1mA	1500	>3	10	4 A			t_f<1μs							102	水平偏向用	○
★	〃 351	〃	PA	〃	650	270	5 A	80W (Tc=25℃)	150	5mA	650	15	5	5 A	10	−500					40*	150		102		
★	〃 352	〃	〃	Ge.A	32	32R	1 A	650	90	25	10	150	0.5	300	2	−10	NF<25dB (f=1kHz, V_{CB}=5V, I_E=−5mA)				f_{ae}>10kHz			12B		
★	〃 353	三洋	〃	Si.TMe	150	150	2 A	60W (Tc=25℃)	150	10	30	40～170	5	1 A	5	−1A					8*			102		
★	〃 354	富士通																								
★	〃 355	三菱	PA	Si.EP	30	25	1 A	800	135	1	25	150	1	500	6	−10					100*			242	2SB525 とコンプリ	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SD356	三菱	PA	Si.EP	90	80	800	10W (Tc=25°C)	150	10	25	100	4	300										180	2SB526 とコンプリ	
	〃 357	〃	〃	〃	110	100	800	10W (Tc=25°C)	150	10	25	100	4	300										180	2SB527 とコンプリ	
	〃 358	〃	〃	〃	130	120	800	10W (Tc=25°C)	150	10	25	100	4	300										180	2SB528 とコンプリ	
	〃 359	〃	〃	〃	40	20	2 A	10W (Tc=25°C)	150	1	25	110	4	500										180	2SB529 とコンプリ	
★	〃 360	〃	〃	〃	40	20	2 A	10W (Tc=25°C)	150	1	25	120	4	500										180		
	〃 361	〃	〃	〃	60	40	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	1	25	110	4	500										180	2SB524 とコンプリ	
★	〃 362	日電	SW.PA	Si.E	150	100	5 A	40W (Tc=25°C)	150	20	100	90	5	5 A	10	−100					15 *			134		
	〃 363	〃	SW	Si.TMe	250	200	30 A	200W (Tc=25°C)	175	100	200	30	5	15 A			t_{on}<2μs, t_{off}<6.5μs t_{stg}<4μs							106		○
	〃 364	〃	〃	〃	450	400	30 A	200W (Tc=25°C)	175	100	400	30	5	15 A			t_{on}<2μs, t_{off}<6.5μs t_{stg}<4μs							106		
★	〃 365	松下	PA	〃	60	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$ 70kHz			268	2SB512 とコンプリ	○
★	〃 366	〃	〃	〃	60	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$ 70kHz			267	2SB513 とコンプリ	○
★	〃 367	〃	〃	Ge.A	25	25R	300	150	85	20	12	150	0.5	150	2	−10	NF<30dB (f=1kHz, V_{CB}=5V, I_E=−5mA)				$f_{\alpha e}$>10kHz			12B		
★	〃 368	三洋	SW	Si.TMe	1300	400	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	100	8	5	4 A			t_f<1.4μs							102	水平偏向用	
	〃 369	東芝	PA	Si.DJ	80	60	10A	100W (Tc=25°C)	150	10A	80	100	5	1 A										102		
★	〃 370	〃																								
	〃 371	〃	PA	Si.TMe	100	100	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	50	40~240	5	1 A	5	−1A					5 *	100		102	2SB531 とコンプリ	
	〃 372	日電	SW	Si.T	150	100	30 A	200W (Tc=25°C)	175	100	100	40	5	15 A										106		
	〃 373	〃	〃	〃	250	200	30 A	200W (Tc=25°C)	175	100	200	40	5	15 A										106		○
	〃 374	〃	〃	〃	450	400	30 A	200W (Tc=25°C)	175	100	400	30	5	15 A										106		
	〃 375	〃	PA.SW	〃	150	100	10A	100W (Tc=25°C)	175	100	100	70	5	5 A	10	−300	t_{on}=0.3μs, t_f=0.2μs t_{stg}=3μs				10 *			102		
	〃 376	〃	〃	〃	250	200	10A	100W (Tc=25°C)	175	100	200	70	5	5 A			t_{on}=0.3μs, t_f=0.2μs t_{stg}=3μs							102		○
	〃 377	〃	〃	〃	450	400	10A	100W (Tc=25°C)	175	100	400	25	5	5 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.4μs t_{stg}=3μs							102		
★	〃 378	日電	PA. SW	Si.E	100	60	2 A	1 W	175	0.5	60	80	2	500										84B		
★	〃 379	松下	PA	Si.EMe	80	80	5 A	60W (Tc=75°C)	150	1mA	50	100	4	1 A	10	−500					10 *			102	2SB532 とコンプリ	
	〃 380	〃	SW	Si.TMe	1500	700	5 A	50W (Tc=75°C)	130	1mA	1500	>5	10	5 A			t_f<0.9μs							102	水平偏向用	○
	〃 381	日電	PA	Si.E	130	120	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	120	110	5	300	5	−100					45 *	25		268	2SB536 とコンプリ	
	〃 382	〃	〃	〃	130	120	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	120	110	5	300	5	−100					45 *	25		267	2SB537 とコンプリ	
★	〃 383	日立	〃	Si.T	300	300	5 A	100W (Tc=25°C)	150	10	250	80	10	500										102		
	〃 384	新電元	PA. SW	Si.DJ ダーリントン	80	80	7 A	30W (Tc=25°C)	150	500	80	5000	5	5 A										204		
	〃 385	〃	〃	〃	100	100	7 A	30W (Tc=25°C)	150	500	100	5000	5	5 A										204		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
2SD386	三洋	PA	Si.TMe	200	120	2 A	25W (Tc=25°C)	150	1mA	180	40~320	2	500										268		○
〃 387	〃	〃	〃	200	120	2 A	25W (Tc=25°C)	150	1mA	180	40~320	2	500										267		○
★ 〃 388	日電	〃	〃	150	100	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	100	80	5	1 A	10	−200					9 *	190		102	2SB541 とコンプリ	
〃 389	松下	〃	Si.DJ	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$ 25kHz			268		○
★ 〃 390	〃	〃	〃	60	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$ 25kHz			267		○
★ 〃 391	三洋																								
★ 〃 392	三菱	PA	Si.EP	20	15	300	300	125	1	20	150	2	150	6	−10					150 *			138B	2SB542 とコンプリ	
★ 〃 393	〃	PA. SW	Si.EbMe	500	350	6 A	100W (Tc=25°C)	150	10	400	7	5	5 A			t_{off}=4μs (I_C=5A, I_{B1}≒−I_{B2}=1.3A)							102		
★ 〃 394	〃	〃	〃	700	400	6 A	100W (Tc=25°C)	150	10	450	7	5	5 A										102		
★ 〃 395	〃	〃	〃	700	400	8 A	100W (Tc=25°C)	150	10	450	8	5	7 A										102		
〃 396	日立	〃	Si.TMe	700	300	15A	125W (Tc=25°C)	150	5	400	30	2	7.5A			t_{on}<15μs, t_{off}<40μs t_{stg}<20μs							102		
★ 〃 397	三洋																								
★ 〃 398	〃																								
★ 〃 399	〃																								
〃 400	〃	PA	Si.EP	25	25	1 A	900	150	1	20	60~560	2	50	10	−50					180 *	15		294	2SB544 とコンプリ	
★ 〃 401	日電	〃	Si.TMe	200	150	2 A	20W (Tc=25°C)	150	50	150	90	10	400	10	−400					5 *			268	2SB546 とコンプリ	○
★ 〃 402	〃	〃	〃	200	150	2 A	20W (Tc=25°C)	150	50	150	90	10	400	10	−400					5 *			267	2SB547 とコンプリ	○
★ 〃 403	三洋																								
★ 〃 404	東芝	PA	Si.DJ	50		6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	200	1	1 A										268		
〃 405	日電	SW.PA	Si.E	70	70	2 A	1 W	175	1	50	4000	2	1 A										84B	ダーリントン	
〃 406	〃	〃	〃	100	100	2 A	1 W	175	1	70	4000	2	1 A										84B	ダーリントン	
★ 〃 407	〃	〃	Si.EMe	100	100	5 A	25W (Tc=25°C)	175	10	80	4000	2	5 A										83	ダーリントン	
★ 〃 408	〃	〃	〃	150	150	5 A	25W (Tc=25°C)	175	10	100	3000	2	5 A										83	ダーリントン	
〃 409	〃	〃	〃	100	100	5 A	30W (Tc=25°C)	175	10	80	4000	2	5 A										134	ダーリントン	
〃 410	〃	〃	〃	150	150	5 A	30W (Tc=25°C)	175	10	100	3000	2	5 A										134	ダーリントン	
〃 411	〃	〃	〃	100	80	10A	80W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	2	10A										102	ダーリントン	
〃 412	〃	〃	〃	150	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	4000	2	15A										102	ダーリントン	
〃 413	富士通	PA. SW	Si.TMe	200	200	500	800	175	5	150	65	5	200	5	−50	t_r<2μs, t_f<2μs t_{stg}<5μs				25 *	12.5		84B		
〃 414	日電	PA	Si.E	120	80	800	10W (Tc=25°C)	150	1	80	90	5	200	5	−100					45 *	15		225		
〃 415	〃	〃	〃	120	100	800	10W (Tc=25°C)	150	1	80	90	5	200	5	−100					45 *	15		225		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SD416	三洋	SW	Si.TMe	1500	400	2 A	50W (Tc=25°C)	150	1mA	1500	5	5	5.5A			t_f<0.8μs							102	
	〃 417	富士通	〃	〃	250	200	7 A	75W (Tc=25°C)	175	10	30	25	5	3 A	6	−300	t_{on}<2.5μs, t_f<2μs t_{stg}<2.5μs				30 *			102	
	〃 418	松下	PA	〃	1000	500	5 A	80W (Tc=25°C)	150	1mA	1000	15	5	5 A			t_f=1.5μs							102	
★	〃 419	サンケン	〃	Si.DJ	100	80	7 A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	100	2500	4	7 A	12	−500					6 *			99	ダーリントン
★	〃 420	〃	〃	〃	120	100	7 A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	120	2500	4	7 A	12	−500					6 *			99	〃
★	〃 421	〃	〃	〃	140	120	7 A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	140	2500	4	7 A	12	−500					6 *			99	〃
	〃 422	富士通	SW	Si.TMe	250	200	4 A	30W (Tc=25°C)	175	100	150	20	5	3 A	6	−300	t_{on}<2.5μs, t_f<2μs t_{stg}<2.5μs				30 *			99	
	〃 423	〃	〃	Si.TP	250	200	4 A	30W (Tc=25°C)	175	100	150	20	5	3 A			t_r<1.5μs, t_f<1μs t_{stg}<1.5μs							99	
	〃 424	東芝	PA	Si.TMe	180	180	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	90	40~140	5	2 A	5	−2A					5 *	300		102	2SB554 とコンプリ
★	〃 425	〃	〃	〃	140	140	12A	100W (Tc=25°C)	150	100	60	40~140	5	2 A	5	−2A					5 *	220		102	2SB555 とコンプリ
★	〃 426	〃	〃	〃	120	120	12A	100W (Tc=25°C)	150	100	60	40~140	5	2 A	5	−2A					5 *	220		102	2SB556 とコンプリ
	〃 427	〃	〃	〃	120	120	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	60	40~140	5	1 A	5	−1A					7 *	170		102	2SB557 とコンプリ
	〃 428	〃	〃	Si.T	100	100	7 A	60W (Tc=25°C)	150	100	50	40~140	5	1 A	5	−1A					7 *	140		102	2SB558 とコンプリ
★	〃 429	日立	PA. SW	〃	800	400	15A	100W (Tc=25°C)	150	5	600	15	5	9 A			t_{on}<20μs, t_{off}<15μs t_{stg}<5μs							102	
★	〃 430	湯浅	PA	Si.TMe	120	80	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	30	60	4	1 A	5	−0.5A					15 *			102	
★	〃 431	〃	〃	〃	120	80	7 A	60W (Tc=25°C)	150	100	30	60	5	1 A	5	−0.5A					20 *			102	
★	〃 432	〃	〃	〃	130	100	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	30	60	5	1 A	5	−0.5A					15 *			102	
★	〃 433	〃	〃	〃	250	150	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	30	60	5	1 A	5	−0.5A					15 *			102	
★	〃 434	〃	〃	〃	200	200	20A	200W (Tc=25°C)	150	100	100	60	5	1 A										102	
★	〃 435	〃	〃	〃	300	300	20A	200W (Tc=25°C)	150	100	100	60	5	1 A										102	
★	〃 436	〃	〃	〃	400	400	20A	200W (Tc=25°C)	150	100	100	60	5	1 A										102	
★	〃 437	三洋	〃	Si. T	600	350	10 A	80W (Tc=25°C)	150	1mA	600	10	5	6 A										102	
	〃 438	〃	〃	Si.EP	100	80	700	900	150	1	20	60~560	5	50	10	−50					100 *	10		294	2SB560 とコンプリ
	〃 439	〃	〃	〃	20	18	1.2A	8 W (Tc=25°C)	150	1	15	150	2	500							150 *			296	
★	〃 440	〃																							
★	〃 441	オリジン																							
★	〃 442	〃																							
★	〃 443	〃																							
★	〃 444	〃																							
★	〃 445	〃																							

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SD446	オリジン																								
★	〃 447	〃																								
★	〃 448	〃																								
★	〃 449	〃																								
★	〃 450	〃																								
★	〃 451	〃																								
★	〃 452	〃																								
★	〃 453	〃																								
★	〃 454	〃																								
★	〃 455	〃																								
★	〃 456	〃																								
	〃 457	日電	PA	Si.TMe	250	200	55A	200W (T_c=25°C)	175	100	200	30	5	50A										106	
★	〃 458	松下	〃	〃	600	400	5 A	80W (T_c=25°C)	150	1mA	600	20	5	5 A										102	
★	〃 459	新電元	PA.SW	Si.DJ	80	80	7 A	50W (T_c=25°C)	150	100	80	5000	5	5 A	10	−1 A	t_{on}<10μs, t_f<10μs t_{stg}<6μs				f_{ae} 20kHz			268	ダーリントン
★	〃 460	〃	〃	〃	100	100	7 A	50W (T_c=25°C)	150	100	100	5000	5	5 A	10	−1 A	t_{on}<10μs, t_f<10μs t_{stg}<6μs				f_{ae} 20kHz			268	〃
★	〃 461	日立	〃	Si.T	250	250	3 A	80W (T_c=25°C)	150	100	250	40~170	5	1 A	5	−1A					1 *	115		102	
★	〃 462	ソニー																								
★	〃 463	新電元	PA.SW	Si.DJ	80	60	7 A	80W (T_c=25°C)	150	500	60	3000	5	5 A	10	−1 A	t_{on}<10μs, t_f<10μs t_{stg}<6μs				f_{ae} 20kHz			102	ダーリントン
★	〃 464	〃	〃	〃	100	80	7 A	80W (T_c=25°C)	150	500	80	3000	5	5 A	10	−1 A	t_{on}<10μs, t_f<10μs t_{stg}<6μs				f_{ae} 20kHz			102	〃
★	〃 465	〃	〃	Si.T	500	400	50A	400W (T_c=25°C)	150	1mA	500	600	5	50A			t_{on}<2.5μs, t_f< 6 μs t_{stg}<12μs							258	〃
★	〃 466	〃	〃	〃	600	450	50A	400W (T_c=25°C)	150	1mA	600	600	5	50A			t_{on}<2.5μs, t_f< 6 μs t_{stg}<12μs							258	〃
	〃 467	日立	PA	Si. E	25	20	700	500	150	1	20	85~240	1	150	1	−150					280 *	12		138	2SB561 とコンプリ
	〃 468	〃	〃	〃	25	20	1 A	900	150	1	20	85~240	2	500	2	−500					190 *	22		251	2SB562 とコンプリ
	〃 469	日電	〃	Si.TMe	150	110	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	110	80	5	1 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.5μs t_{stg}= 3 μs							102	
★	〃 470	松下	SW	Si. Me	1600	700	1 A	15W (T_c=25°C)	130	100	750	2	5	1 A			t_{stg}<10μs t_f<1.5μs							288	○
	〃 471	日電	PA	Si. E	30	25	1 A	1 W	150	0.1	30	200	1	100	6	−10					130 *	22		278	2SB564 とコンプリ
	〃 472	日立	SW	Si. T	150	100	10A	80W (T_c=25°C)	150	100	150	>1000	2	5 A			t_{on}= 2 μs t_{off}= 9 μs							102	ダーリントン ダンパ内蔵
	〃 473	〃	〃	〃	100	100	15A	100W (T_c=25°C)	150	100	100	4000	2	15A			t_{on}= 2 μs, t_{off}= 9 μs							102	ダーリントン ダンパ内蔵
★	〃 474	〃																								
★	〃 475	〃	PA	Si. T	50	50	4 A	40W (T_c=25°C)	150	100	20	100	4	1 A										267	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SD476	日立	PA	Si.T	70	50	4 A	40W (Tc=25°C)	150	1	50	60~200	4	1 A	4	−500					7 *			268	2SB566 とコンプリ
★	〃 477	〃	〃	〃	200	150	2 A	30W (Tc=25°C)	150	1	120	150	4	50										267	
★	〃 478	〃	〃	〃	200	150	2 A	30W (Tc=25°C)	150	1	120	60~320	4	50								22		268	2SB568 とコンプリ
★	〃 479	モトローラ	〃	Si.E	40	40	4 A	40W (Tc=25°C)	150	500	40	6000	3	2 A					JEDEC 2N6037相当 ダーリントン接続					252	2SB569 とコンプリ
★	〃 480	〃	〃	〃	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	500	60	6000	3	2 A					JEDEC 2N6038相当 ダーリントン接続					252	2SB570 とコンプリ
★	〃 481	〃	〃	〃	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	500	80	6000	3	2 A					JEDEC 2N6039相当 ダーリントン接続					252	2SB571 とコンプリ
★	〃 482	〃	〃	Si.TP	275	250	500	20W (Tc=25°C)	150	10	275	80	10	100					JEDEC 2N5650相当					252	
★	〃 483	〃	〃	〃	325	300	500	20W (Tc=25°C)	150	10	325	80	10	100					〃 2N5656 〃					252	
★	〃 484	〃	〃	〃	375	350	500	20W (Tc=25°C)	150	10	375	80	10	100					〃 2N5657 〃					252	
★	〃 485	〃	〃	Si.E	40	40	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	50	2	1.5A					〃 2N5190 〃					252	2SB575 とコンプリ
★	〃 486	〃	〃	〃	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	50	2	1.5A					〃 2N5191 〃					252	2SB576 とコンプリ
★	〃 487	〃	〃	〃	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	50	2	1.5A					〃 2N5192 〃					252	2SB577 とコンプリ
★	〃 488	〃	〃	〃	40	40	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	50	1	500					〃 2N4921 〃					252	2SB572 とコンプリ
★	〃 489	〃	〃	〃	60	60	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	60	50	1	500					〃 2N4922 〃					252	2SB573 とコンプリ
★	〃 490	〃	〃	〃	80	80	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	50	1	500					〃 2N4923 〃					252	2SB574 とコンプリ
★	〃 491	〃	〃	〃	70	60	10A	90W (Tc=25°C)	150	1mA	70	40	4	4 A					モトローラ MJE3055 〃					253	2SB578 とコンプリ
★	〃 492	〃	〃	〃	100	60	15A	115W (Tc=25°C)	200	1mA	100	40	4	4 A					JEDEC 2N3055 〃					102	
★	〃 493	〃	〃	〃	60	40	5 A	75W (Tc=25°C)	150	100	60	40	2	2.5A					〃 2N5977 〃					253	2SB579 とコンプリ
★	〃 494	〃	〃	〃	80	60	5 A	75W (Tc=25°C)	150	100	80	40	2	2.5A					〃 2N5978 〃					253	2SB580 とコンプリ
★	〃 495	〃	〃	〃	100	80	5 A	75W (Tc=25°C)	150	100	100	40	2	2.5A					〃 2N5979 〃					253	2SB581 とコンプリ
★	〃 496	〃	〃	〃	60	60	8 A	75W (Tc=25°C)	150	500	60	3000	4	4 A					モトローラ MJE3043相当 ダーリントン接続					253	2SB582 とコンプリ
★	〃 497	〃	〃	〃	80	80	8 A	75W (Tc=25°C)	150	500	80	3000	4	4 A					モトローラ MJE3044相当 ダーリントン接続					253	2SB583 とコンプリ
★	〃 498	〃	〃	〃	100	100	8 A	75W (Tc=25°C)	150	500	100	3000	4	4 A					モトローラ MJE3045相当 ダーリントン接続					253	2SB584 とコンプリ
★	〃 499	〃	〃	〃	60	40	8 A	90W (Tc=25°C)	150	100	60	60	2	4 A					JEDEC 2N5983相当					253	
★	〃 500	〃	〃	〃	80	60	8 A	90W (Tc=25°C)	150	100	80	60	2	4 A					〃 2N5984 〃					253	
★	〃 501	〃	〃	〃	100	80	8 A	90W (Tc=25°C)	150	100	100	60	2	4 A					〃 2N5985 〃					253	
★	〃 502	〃	〃	〃	60	60	8 A	100W (Tc=25°C)	200	500	60	3000	3	4 A					JEDEC 2N6055相当 ダーリントン接続					102	2SB585 とコンプリ
★	〃 503	〃	〃	〃	80	80	8 A	100W (Tc=25°C)	200	500	80	3000	3	4 A					JEDEC 2N6056相当 ダーリントン接続					102	2SB586 とコンプリ
★	〃 504	〃	〃	〃	60	60	12A	150W (Tc=25°C)	200	500	60	3000	3	6 A					JEDEC 2N6057相当 ダーリントン接続					102	2SB587 とコンプリ
★	〃 505	〃	〃	〃	80	80	12A	150W (Tc=25°C)	200	500	80	3000	3	6 A					JEDEC 2N6058相当 ダーリントン接続					102	2SB588 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SD506	モトローラ	PA	Si. E	100	100	12A	150W (Tc=25°C)	200	500	100	3000	3	6 A					JEDEC 2N6059相当 ダーリントン接続					102	2SB589 とコンプリ
	〃 507	三菱	PA. SW	Si. DJ	90	80	250A	625W (Tc=25°C)	150	2mA	90	13	4	150A				t_{on}< 5 μs t_{off}<10μs						286	
	〃 508	〃	〃	〃	110	100	250A	625W (Tc=25°C)	150	2mA	110	13	4	150A				t_{on}< 5 μs t_{off}<10μs						286	
	〃 509	〃	〃	〃	130	120	250A	625W (Tc=25°C)	150	2mA	130	13	4	150A				t_{on}< 5 μs t_{off}<10μs						286	
	〃 510	〃	〃	〃	150	140	250A	625W (Tc=25°C)	150	2mA	150	13	4	150A				t_{on}< 5 μs t_{off}<10μs						286	
	〃 511	〃	〃	〃	90	80	250A	625W (Tc=25°C)	150	2mA	90	13	4	200A				t_{on}< 5 μs t_{off}<10μs						286	
	〃 512	〃	〃	〃	110	100	250A	625W (Tc=25°C)	150	2mA	110	13	4	200A				t_{on}< 5 μs t_{off}<10μs						286	
	〃 513	〃	〃	〃	130	120	250A	625W (Tc=25°C)	150	2mA	130	13	4	200A				t_{on}< 5 μs t_{off}<10μs						286	
	〃 514	〃	〃	〃	90	80	250A	625W (Tc=25°C)	150	2mA	90	15	4	250A				t_{on}< 5 μs t_{off}<10μs						286	
	〃 515	〃	〃	〃	110	100	250A	625W (Tc=25°C)	150	2mA	110	15	4	250A				t_{on}< 5 μs t_{off}<10μs						286	
★	〃 516	日電																							
★	〃 517	松下	SW	Si.TMe	1500	700	3 A	16W (Tc=25°C)	130	50	750	6	5	2 A				t_{stg}< 13μs t_f<0.9μs						102	水平偏向用
	〃 518	富士通	〃	Si. TP	220	200	4 A	30W (Tc=25°C)	175	100	150	20	5	3 A				t_r<2.5μs t_f<2μs t_{stg}<2.5μs						99	
★	〃 519	〃	〃	Si.TMe	600	400	10A	100W (Tc=25°C)	175	200	600	15	5	5 A				t_{on}<3.5μs, t_f<2.5μs t_{stg}< 4 μs						102	
★	〃 520	三菱	〃	Si. T	600	400	7 A	100W (Tc=25°C)	150	500	600	750	2	4.5A										102	ダーリントン
★	〃 521	〃																							
	〃 522	東芝	PA	Si. DJ	100	60	10A	100W (Tc=25°C)	150	10mA	100	40	5	5 A										102	ダーリントン
	〃 523	〃	〃	Si.T	80	80	7 A	50W (Tc=25°C)	150	100	80	2000～15000	3	3 A										102	ダーリントン
	〃 524	〃	〃	〃	80	80	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	80	>2000	3	5 A										102	ダーリントン
	〃 525	〃	〃	〃	100	100	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	40～240	5	1 A	5	−1A					12 *	100		268	2SB595 とコンプリ
	〃 526	〃	〃	〃	80	80	4 A	30W (Tc=25°C)	150	30	80	40～240	5	500	5	−500					8 *	90		268	2SB596 とコンプリ
★	〃 527	〃						100W (Tc=25°C)																	
★	〃 528	日立	PA	Si. T	600	500	8 A	100W (Tc=25°C)	150	0.5	400	500	3	6 A										102	ダーリントン
★	〃 529	ソニー	PA. SW		850	320	5 A	85W (Tc=25°C)	120	100	650	30	5	100				t_{stg}< 5 μs t_f<0.5μs						102	
★	〃 530	富士通																							
★	〃 531	ソニー	PA	Si. T	100	60	5 A	43W (Tc=25°C)	120	2	50	100	2	100										268	
★	〃 532	〃	〃	Si. TMe	200	70	7 A	70W (Tc=25°C)	120	10	100	80	2	1 A	5	−3A					4.5 *	140		102	
★	〃 533	〃	〃	Si.T	270	90	10A	100W (Tc=25°C)	120	1mA	240	100	2	1 A	5	−100					8 *	260		102	
★	〃 534	〃	〃	Si. EMe	110	110	12A	100W (Tc=25°C)	120	100	50	90	2	1 A	2	−5A					5 *			102	
	〃 535	日電	〃	Si.TMe	250	120	12A	150W (Tc=25°C)	150	100	120	75	5	2 A				t_{on}=1.5μs, t_{off}= 8 μs t_{stg}=4.5μs						102	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SD536	富士通	SW	Si.TP	200	200	10A	100W (Tc=25°C)	175	1 mA	200	50	5	5 A			t_r=0.3μs, t_f=0.3μs t_{stg}=1.5μs							102	
	〃 537	〃	〃	〃	200	150	10A	100W (Tc=25°C)	175	1 mA	200	50	5	5 A			t_r=0.3μs, t_f=0.3μs t_{stg}=1.5μs							102	
	〃 538	〃	〃	Si.TMe	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	175	500	150	15	5	5 A			t_r<2.2μs, t_f<1.5μs t_{stg}<3μs							102	○
	〃 539	〃	〃	〃	400	350	10A	100W (Tc=25°C)	175	500	150	15	5	5 A			t_r<2.2μs, t_f<1.5μs t_{stg}<3μs							102	○
	〃 540	〃	〃	Si.TP	200	200	30A	200W (Tc=25°C)	175	3 mA	200	40	5	10A			t_r=0.7μs, t_f=0.7μs t_{stg}=1.5μs							266	
	〃 541	〃	〃	〃	200	150	30A	200W (Tc=25°C)	175	3 mA	200	40	5	10A			t_r=0.7μs, t_f=0.7μs t_{stg}=1.5μs							266	
	〃 542	〃	〃	〃	400	400	30A	200W (Tc=25°C)	175	3 mA	400	25	5	10A			t_r=1μs, t_f=1μs t_{stg}=2μS							266	
	〃 543	〃	〃	〃	400	350	30A	200W (Tc=25°C)	175	3 mA	400	25	5	10A			t_r=1μs, t_f=1μs t_{stg}=2μs							266	
★	〃 544	ソニー	PA	Si. T	100	60	5 A	43W (Tc=25°C)	120	2	50	100	2	100										267	
	〃 545	三洋	〃	Si.EP	25	25	1 A	600	150	1	20	60~320	2	50	10	−50					180*	15		138	2SB598とコンプリ
★	〃 546	松下	SW	Si.TMe	800	500	1 A	30W (Tc=25°C)	150	300	800	40~200	10	20	10	−100					7*			134	
	〃 547	東芝	〃	〃	600	450	+50A −47A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	>150	5	50A			t_{on}=1μs, t_f=2.5μs t_{stg}=8μs							319	
	〃 548	〃	〃	〃	600	450	120A	770W (Tc=25°C)	125	2 mA	600	500	5	60A			t_{on}=3μs, t_f=8μs t_{stg}=12μs							158	ダーリントン
★	〃 549	〃	SW.PA	Si. E	30	30	1.5A	1 W	150	10	30	>4000	2	150			t_{on}=0.18μs, t_f=0.3μs t_{stg}=0.6μs							342	ダーリントン
★	〃 550	〃	PA.SW	Si. T	100	100	7 A	40W (Tc=25°C)	150	50	100	120	5	1 A			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<9μs							99	
	〃 551	〃	PA	Si.TMe	150	150	12A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	40~140	5	1 A	10	−1A					15*	250		102	2SB681とコンプリ
	〃 552	〃	〃	〃	220	180	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	150	25~80	5	5 A	10	−1 A					4*	160		102	2SB552とコンプリ
	〃 553	〃	PA.SW	Si. T	70	50	7 A	40W (Tc=25°C)	150	30	70	70~240	1	1 A	4	−1A	t_{on}=0.2μs, t_f=0.5μs t_{stg}=2.5μs				10*	250		268	2SB553とコンプリ
★	〃 554	日電	PA	〃	250	200	2 A	30W (Tc=25°C)	150	10	200	80	5	300										134	2SB599とコンプリ
	〃 555	〃	〃	〃	250	200	10A	200W (Tc=25°C)	150	50	200	70	5	2 A	5	−200					15*	300		102	2SB600とコンプリ
★	〃 556	サンケン	〃	Si.DJ	110	80	15A	120W (Tc=25°C)	175	1 mA	110	30	4	5 A	12	−500					8			102	
★	〃 557	〃	〃	〃	140	100	15A	120W (Tc=25°C)	175	1 mA	140	30	4	5 A	12	−500					8			102	
★	〃 558	日電	PA.SW	Si.E	90	70	2 A	1 W	150	1	70	4000	2	1 A			t_{on}=0.4μs, t_f=1μs t_{stg}=1μs							65	ダーリントン
★	〃 559	〃																							
	〃 560	日電 富士通	PA.SW	Si.E ダーリントン	150	100	5 A	30W (Tc=25°C)	150	1	100	4000	2	3 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1μs t_{stg}=1μs							268	2SB601とコンプリ
★	〃 561	日電																							
★	〃 562	〃																							
★	〃 563	〃																							
★	〃 564	〃																							
★	〃 565	〃	PA.SW	Si.T	400	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	>100	1.5	6 A										102	ダーリントン

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SD566	日電																								
★	〃 567	〃																								
	〃 568	〃	PA.SW	Si.E	100	60	7A	40W (T_c=25°C)	150	10	80	40~200	1	3A										268	2SB707 とコンプリ	
	〃 569	〃	〃	〃	100	80	7A	40W (T_c=25°C)	150	10	80	40~200	1	3A										268	2SB708 とコンプリ	
★	〃 570	松下	PA	Si.TMe	70	70	4A	30W (T_c=25°C)	150	1mA	70	120	5	500	5	−500					10*			268		
	〃 571	日電	〃	Si.E	60	50	700	1W	150	0.1	60	200	1	100	6	−10					110*	13		278	2SB605 とコンプリ	
★	〃 572	新電元	PA.SW	Si.T	500	400	15A	150W (T_c=25°C)	150	1mA	500	150	5	15A			t_{on}<2μs, t_{stg}<15μs		t_f<10μs					102	ダーリントン	
★	〃 573	〃	〃	〃	600	450	15A	150W (T_c=25°C)	150	1mA	600	150	5	15A			t_{on}<2μs, t_{stg}<15μs		t_f<10μs					102	ダーリントン	
	〃 574	〃	〃	Si.DJ	120	120	30A	400W (T_c=25°C)	150	5mA	120	800	3	15A			t_{on}<2μs, t_{stg}<4.5μs		t_f<5μs					266	ダーリントン	○
★	〃 575	三洋	SW	Si.TMe	1400	600	2.5A	50W (T_c=25°C)	150	50	1000	>2.5	5	2A			t_f<1μs							102	水平偏向用	
	〃 576	富士通	〃	Si.EP	250	250	500	800	175	0.5	200	70	10	10			t_{on}<0.2μs, t_{stg}<2μs		t_{off}<3μs					84C	2SB606 とコンプリ	
★	〃 577	松下	〃	Si.Me	1500	1500S	3A	16W (T_c=25°C)	115	100	750	7	10	3A			t_{stg}<20μs,		t_f<1μs					102		
★	〃 578	日立	PA	Si.T	180	140	2A	30W (T_c=25°C)	150	1	120	60~320	4	50										268	2SB608 とコンプリ	
★	〃 579	〃	〃	Si.E	100	80	4A	40W (T_c=25°C)	150	I_{CEO} 100	V_{CE} 80	60~320	4	50										153	2SB609 とコンプリ	
	〃 580	富士通	〃	Si.DJ	60		1A	20W (T_c=25°C)	175	20	30	100	4	500		−100					1.2*			83		
★	〃 581	日立	〃	Si.E	150	100	7A	60W (T_c=25°C)	150	10	120	120	5	1A										102		○
★	〃 582	〃	〃	〃	180	140	12A	100W (T_c=25°C)	150	10	160	100	5	1A										102		
★	〃 583	〃	〃	〃	250	200	15A	150W (T_c=25°C)	150	10	220	120	5	2A										102		
★	〃 584	三菱																								
★	〃 585	〃																								
★	〃 586	日電	PA	Si.E	100	80	5A	60W (T_c=25°C)	150	10	80	80	5	1A	5	−100					15*	75		295	2SB616 とコンプリ	○
★	〃 587	〃	〃	〃	120	100	6A	70W (T_c=25°C)	150	50	100	80	5	1A	5	−200					17*	130		295	2SB617 とコンプリ	○
★	〃 588	〃	〃	Si.T	150	120	7A	80W (T_c=25°C)	150	50	120	80	5	1A	5	−200					15*	190		295	2SB618 とコンプリ	○
★	〃 589	松下	SW	Si.Me	1500		5A	50W (T_c=25°C)	130	100	750	7	10	5A			t_{stg}<15μs,		t_f<0.9μs					102		
	〃 590	富士通	〃	Si.EP	100		2A	1W	200	1	90	110	2	2A			t_{on}<150ns, t_{stg}<1.8μs		t_{off}<2.1μs					84C		
	〃 591	松下	LN	〃	30	20	50	150	125	1	10	300	5	2	10	−1	NF=2dB (f=1kHz, V_{CB}=5V, I_E=−2mA)				150*	2.2	70	138		
	〃 592	〃	PA	〃	30	25	1A	750	150	0.1	20	160	10	500	5	−1	h_{fe}=5kΩ h_{oe}=0.06μS h_{re}=1.5×10⁻⁴				200*	20		138	2SB621 とコンプリ	○
★	〃 593	サンケン	〃	Si.TMe	500	400	300	800	150	100	500	50	4	50	5	−100					5*			84B	2SB622 とコンプリ	
★	〃 594	〃	〃	〃	800	700	300	800	150	100	800	50	4	50	5	−100					5*			84B		
★	〃 595	日電																								

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25℃) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (℃)	電気的特性 (T_a = 25℃) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SD597	松下	PA		100	100	5A	60W (T_c=25℃)	150	1mA	60	40～200	5	1A	10	−500					7 *			102	2SB625とコンプリ	
★	〃 598	〃	〃		120	120	6A	80W (T_c=25℃)		1mA	70	40～200	5	1A	10	−500					6 *			102	2SB626とコンプリ	
	〃 599	三洋		Si.EP	25		1A	350	125	1	20	150	2	50	10	−50					180 *	15		138		
	〃 600	〃	〃	〃	100	100	1A	8W (T_c=25℃)	150	1	50	60～320	5	50	10	−50					130 *	20		296	2SB631とコンプリ	
	〃 601	松下	AF	〃	30	25	100	200	125	1	10	160～460	10	2	10	−2	V_{NO}<300mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				150 *	3.5		176	2SB709とコンプリ	○
	〃 602	〃	〃	〃	30	25	500	200	125	0.1	20	160	10	150	10	−50					200 *	6		176	2SB710とコンプリ	○
★	〃 603	〃	〃	〃	30	30	100	250	125	1	10	360	10	2	5	−2	h_{ie}=4kΩ h_{oe}=0.15μS h_{re}=0.8×10⁻⁴				150 *	3.5		276		
★	〃 604	日立	PA	Si.T	180	180	5A	100W (T_c=25℃)	150	500	180	400～3200	4	1A	4	−1A					8 *	150		102		
★	〃 605	サンケン	〃	Si.TMe	600	500	7A	80W (T_c=25℃)	150	500	600	400	2	4A										102	ダーリントン	
★	〃 606	〃	〃	〃	600	500	15A	100W (T_c=25℃)	150	500	600	400	2	5A										102	ダーリントン	
★	〃 607	日電																								
	〃 608	〃	PA	Si.E	160	160	1.5A	20W (T_c=25℃)	150	1	120	80	5	300	5	−100					45 *	25		268	2SB628とコンプリ	
★	〃 609	〃																								
★	〃 610	〃	PA	Si.T	250	200	2A	25W (T_c=25℃)	150	1	150	80	10	500	10	−500					5 *	45		268	2SB630とコンプリ	
★	〃 611	富士通	〃	Si.DJ	100		7A	30W (T_c=25℃)	175	20	30	>30	4	500							1.5			99		○
	〃 612	三洋	〃	Si.EP	25	25	2A	10W (T_c=25℃)	150	1	20	60～320	2	500	10	−50					100 *	30		296	2SB632とコンプリ	
	〃 613	〃	〃	〃	100	85	6A	40W (T_c=25℃)	150	100	40	40～320	5	1A	5	−1A					15 *	110		268	2SB633とコンプリ	
★	〃 614	サンケン	〃	Si.TMe	100	80	3A	800	150	100	100	3000	4	3A	5	−100					15 *			84B	ダーリントン	
★	〃 615	〃	〃	〃	140	120	3A	800	150	100	140	3000	4	3A	5	−100					15 *			84B	ダーリントン	
★	〃 616	三洋	〃	Si.EMe	120	100	7A	60W (T_c=25℃)	150	100	80	40～320	5	1A	5	−1A					15 *					
★	〃 617	サンケン	〃	Si.TMe	120	100	8A	100W (T_c=25℃)	150	100	120	2500	4	1A										102	ダーリントン	
★	〃 618	富士通																								
★	〃 619	〃	AF. PA	Si.EP	80	60	1.5A	500	150	1	60	150	1	200	10	−50					100 *	<25	<30 *	138		
	〃 620	〃	PA	〃	80	60	1.5A	1W	150	1	60	150	1	200	10	−50					100 *	<25	<30 *	328		
★	〃 621	三洋	SW	Si.TMe	2500	900	3A	50W (T_c=25℃)	150	50	1000	3～15	10	1.5A			t_f<1μs							102	水平偏向用	
	〃 622	富士通	〃	〃	450	400	3A	30W (T_c=25℃)	175	10	150	20	5	1A			t_r<2.2μs, t_f<2μs t_{stg}<3.5μs							99		
★	〃 623	三菱																								
	〃 624	富士通	SW	Si.TMe	200	150	500	800	175	5	150	180	5	200	5	−50	t_r<0.8μs, t_f<1.5μs t_{stg}<5μs				50 *	12.5		84C		
★	〃 625	ソニー	AF	Si.E	250	70	4A	6.2W (T_c=25℃)	100	3	50	90	2	100	10	−50					60 *	35	$C_c r_{bb'}$ 50ps	84B		
★	〃 626	三洋	SW	Si.TMe	600	350	6A	80W (T_c=25℃)	150	100	350	>300	2	3.5A			t_{on}<1μs, t_f<5μs t_{stg}<40μs							102	ダーリントン	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SD627	三洋	SW	Si.TMe	1500	600	3 A	50W (Tc=25°C)	150	50	1000	5 ~ 25	10	2 A			t_f < 1 μs							102	
	〃 628	日立	PA	Si. E	100	100	10A	80W (Tc=25°C)	150	100	100	1000~20000	3	5 A			t_{on} = 2 μs, t_{off} = 8 μs							102	ダーリントン ダンパ内蔵
	〃 629	〃	〃	〃	100	100	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	1000~20000	3	5 A			t_{on} = 2 μs, t_{off} = 8 μs							102	ダーリントン ダンパ内蔵
	〃 630	富士通	〃	Si. DJ	50	40	30A	200W (Tc=25°C)	175	100	30	25	5	15A										103	
	〃 631	〃	〃	〃	60	50	40A	200W (Tc=25°C)	175	100	30	40	5	15A										103	
★	〃 632	松下	〃	Si.TMe	350	300	2.5A	80W (Tc=25°C)	150	1mA	350	120	15	500										102	
	〃 633	東芝	PA. SW	Si. T	100	100	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	2000~15000	3	3 A			t_{on} = 0.8 μs, t_f = 2.5 μs t_{stg} = 3 μs							268	ダーリントン
	〃 634	〃	〃	〃	80	80	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	2000~15000	3	3 A			t_{on} = 0.8 μs, t_f = 2.5 μs t_{stg} = 3 μs							268	ダーリントン
	〃 635	〃	〃	〃	60	60	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	2000~15000	3	3 A			t_{on} = 0.8 μs, t_f = 2.5 μs t_{stg} = 3 μs							268	ダーリントン
	〃 636	松下	PA	Si. EP	30	25	100	400	135	1	20	250	10	2	5	−2	250	5 k	0.4	20	150*	3.5	70	151	
	〃 637	〃	〃	〃	60	50	100	400	135	1	20	250	10	2	5	−2	250	5 k	0.4	20	150*	3.5	70	151	
	〃 638	〃	〃	〃	30	25	500	600	135	0.1	20	160	10	150	10	−50					200*	6	3.5k*	151	2SB643 とコンプリ
	〃 639	〃	〃	〃	60	50	500	600	135	0.1	20	160	10	150	10	−50					200*	6	3.5k*	151	2SB644 とコンプリ
	〃 640	東芝	PA	Si.TMe	600	400	7 A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	25~140	5	1 A	10	−500					3*	70		102	
	〃 641	〃	SW	〃	600	400	15A	150W (Tc=25°C)	150	500	500	20~140	5	5 A	10	−500	t_{on} = 0.8 μs, t_f = 0.6 μs t_{stg} = 3.5 μs				4*	150		102	
	〃 642	〃	〃	〃	600	400	40A	300W (Tc=25°C)	150	1mA	600	>10	5	30A			t_{on} = = 1.2 μs, t_f = 0.8 μs t_{stg} = 4 μs					400		266	
	〃 643	〃	〃	〃	300	200	30A	300W (Tc=25°C)	150	600	300	>150	5	30A			t_{on} = 1 μs, t_f = 3.5 μs t_{stg} = 7 μs					450		266	ダーリントン
	〃 644	〃	〃	〃	600	450	30A	300W (Tc=25°C)	150	600	600	>150	5	30A			t_{on} = 1.5 μs, t_f = 5 μs t_{stg} = 9 μs					350		266	ダーリントン
	〃 645	〃	〃	〃	600	450	30A	350W (Tc=25°C)	150	600	600	>150	5	30A			t_{on} = 1.5 μs, t_f = 5 μs t_{stg} = 9 μs							319	ダーリントン
★	〃 646	〃	〃	〃	600	450	50A	400W (Tc=25°C)	150	1mA	600	>150	5	50A			t_{on} = 1.5 μs, t_f = 5 μs t_{stg} = 8 μs					600		319	ダーリントン ○
★	〃 647	〃	〃	〃	800	600	100A	770W (Tc=25°C)	125	2mA	800	>100	5	100A			t_{on} = 3 μs, t_f = 15 μs t_{stg} = 20 μs							158	ダーリントン
★	〃 648	〃	〃	〃	300	300	400A	2500W (Tc=25°C)	125	10mA	300	400	5	400A			t_{on} = 1 μs, t_f = 2 μs t_{stg} = 6 μs							156	ダーリントン
★	〃 649	松下	〃	〃	1500	600	3 A	35W (Tc=25°C)	130	100	750	7	10	3 A			t_f < 1 μs t_{stg} < 18 μs							102	水平偏向用
	〃 650	日立	〃	Si. T	400	400	6 A	80W (Tc=25°C)	150	5	300	>500	2	4 A										102	ダーリントン ダンパ内蔵
★	〃 651	〃	PA. SW	〃	400	400	4 A	30W (Tc=25°C)	150	5	300	>500	2	3 A										153	ダーリントン
	〃 652	〃	PA	Si. T	500	500	6 A	80W (Tc=25°C)	150	100	400	3000	2	4 A										102	ダーリントン
★	〃 653	〃																							
	〃 654	三菱	PA	Si. EP	50	30	500	570	150	0.1	30	100	10	1	10	−30					190*	15		84B	
	〃 655	日立	AF. PA	Si. E	30	15	700	500	150	1	20	250~1200	1	150	1	−150					250*			138	
★	〃 656	東芝	PA	Si. T	200	180	1.5A	30W (Tc=25°C)	150	10	150	40~180	10	500	10	−500					> 2*			99	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SD657	東芝	PA	Si.TMe	200	200	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	200	40~180	10	500										102		
★	〃 658	日立	〃	Si.T	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CBX} 100	1500	6 ~60	10	100										102		
★	〃 659	富士通																								
★	〃 660	〃	SW	Si.EP	90	70	2 A	1 W	200	1	70	>60	2	2 A			t_{on}=1.5μs, t_{off}=2.1μs t_{stg}=1.8μs					<80		84C		
	〃 661	松下	LN	〃	35	35	100	400	150	0.1	10	540	5	2	5	−2		5.5k	0.4	25	150 *	2.2	70	151		
	〃 662	〃	PA	Si.TP	250	200	70	600	150	10	250	100	10	5	10	−10	35	300	0.4	2.7	80 *	5	$C_c r_{bb'}$ 60ps	151		
	〃 663	富士電機	PA. SW	〃	500	500	6 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	500	>400	1.5	4 A			t_{on}<3μs, t_f<10μs t_{stg}<15μs							102	ダーリントン	
★	〃 664	東芝	SW	Si.T	80	80	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	2000~15000	3	3 A			t_{on}=0.8μs, t_f=2.5μs t_{stg}=3μs							99	ダーリントン	
★	〃 665	〃	PA	Si.TMe	200	200	15A	150W (Tc=25°C)	150	100	100	40~140	5	1 A	10	−1A					15 *	300		102	2SB645 とコンプリ	
	〃 666	日立	〃	Si. E	120	80	50	900	150	10	100	60~320	5	10	5	−10					140 *	3		251	2SB646 とコンプリ	○
	〃 667	〃	〃	〃	120	80	1 A	900	150	10	100	60~320	5	150	5	−150					140 *	12		251	2SB647 とコンプリ	○
	〃 668	〃	〃	〃	180	120	50	1 W	150	10	160	60~320	5	10	10	−10					140 *	3.5		160	2SB648 とコンプリ	○
	〃 669	〃	〃	〃	180	120	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	10	160	60~320	5	150	5	−500					140 *	14		160	2SB649 とコンプリ	○
	〃 670	〃	〃	〃	100	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	1000~20000	3	8 A			t_{on}= 2 μs, t_{off}= 8 μs							102	ダーリントン ダンパ内蔵	
★	〃 671	松下	SW	Si.EP	30	18	500	600	135	0.1	25	280~700	2	50	10	−50					150 *	6		138		
★	〃 672	〃	PA	Si.TMe	300	300R	1 A	40W (Tc=25°C)	150	5mA	300	150	5	100	10	−100					20 *			102		
★	〃 673	日立	〃	Si. T	120	100	7 A	60W (Tc=25°C)	150	1mA	100	60~200	5	1 A										102	2SB653 とコンプリ	○
★	〃 674	〃	〃	〃	120	120	7 A	80W (Tc=25°C)	150	1mA	100	60~200	5	1 A										102	2SB654 とコンプリ	○
★	〃 675	〃	〃	〃	160	140	12A	100W (Tc=25°C)	150	1mA	140	60~200	5	1 A										102	2SB655 とコンプリ	○
★	〃 676	〃	〃	〃	160	160	12A	125W (Tc=25°C)	150	1mA	140	60~200	5	1 A										102	2SB656 とコンプリ	○
	〃 677	富士電機	SW	Si.TP	450	400	5 A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	>10	4	2 A			t_{on}<1.5μs, t_f<1.5μs t_{stg}<6.5μs							102		
★	〃 678	松下	PA	Si.EMe	60	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	200	60	4000	3	500	3	−1.5A					$f_{\alpha e}$ 100kHz			268	ダーリントン	○
★	〃 679	〃	〃	〃	70	70	4 A	40W (Tc=25°C)	150	200	70	4000	3	1 A	3	−3A					$f_{\alpha e}$ 100kHz			268	ダーリントン	○
★	〃 680																									
★	〃 681																									
★	〃 682																									
	〃 683	東芝	PA.SW	Si.TMe	600	400	15A	150W (Tc=25°C)	150	500	600	>500	5	5 A			t_{on}=0.4μs, t_f= 3 μs t_{stg}=15μs							102	ダーリントン	○
	〃 684	〃	〃	〃	600	300	6 A	30W (Tc=25°C)	150	500	600	>1500	2	2 A			t_{on}= 1 μs, t_f= 5 μs t_{stg}= 8 μs							99	ダーリントン	○
	〃 685	〃	〃	〃	600	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	500	600	>400	2	4 A			t_{on}= 1 μs, t_f= 5 μs t_{stg}=12μs							102	ダーリントン	
	〃 686	〃	〃	Si. E	100	80	4 A	30W (Tc=25°C)	150	20	100	>2000	2	1 A			t_{on}=0.2μs, t_f=0.6μs t_{stg}=1.5μs							268	ダーリントン	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SD687	東芝	PA.SW	Si.E	60	40	3 A	25W (Tc=25°C)	150	20	60	>2000	2	1 A			t_{on}=0.1μs, t_f=0.2μs t_{stg}=1μs							268	ダーリントン
	〃 688	〃	〃	〃	100	100	1.5A	800	175	10	100	>2000	2	100			t_{on}=0.3μs, t_f=0.7μs t_{stg}=2μs							84B	ダーリントン 2SB678とコンプリ
	〃 689	〃	〃	〃	100	100	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	100	>2000	2	100			t_{on}=0.3μs, t_f=0.7μs t_{stg}=2μs							268	ダーリントン 2SB679とコンプリ
★	〃 690	〃	〃	Si.T	70	50	7 A	40W (Tc=25°C)	150	30	70	70~240	1	1 A			t_{on}=0.2μs, t_f=0.5μs t_{stg}=2.5μs					250		99	
★	〃 691	松下	PA	Si.DJ	100	80R	6 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	4000	4	1 A										288	ダーリントン ダンパ内蔵
★	〃 692	〃	〃	〃	100	80R	6 A	50W (Tc=25°C)	150	10	100	4000	4	1 A										102	ダーリントン ダンパ内蔵
★	〃 693	〃	SW	Si.TMe	450	450	10A	80W (Tc=25°C)	150	I_{CER} 1 mA	450	>150	5	5 A										102	ダーリントン ダンパ内蔵
★	〃 694	東芝	〃	〃	400	350	30A	300W (Tc=25°C)	150	600	400	>150	5	30A			t_{on}=1.5μs, t_f=5μs t_{stg}=9μs					350		266	ダーリントン
★	〃 695	〃	〃	〃	400	350	30A	350W (Tc=25°C)	150	1mA	400	>150	5	30A			t_{on}=1.5μs, t_f=5μs t_{stg}=9μs							319	ダーリントン
★	〃 696	〃	〃	〃	400	350	50A	400W (Tc=25°C)	150	1mA	400	>150	5	50A			t_{on}=1.5μs, t_f=5μs t_{stg}=8μs					600		319	ダーリントン ○
★	〃 697	〃	〃	〃	500	450	100A	770W (Tc=25°C)	125	2mA	500	>100	5	100A			t_{on}=3μs, t_f=15μs t_{stg}=20μs							158	ダーリントン
	〃 698	〃	〃	〃	200	200	600A	2500W (Tc=25°C)	125	5 mA	200	400	5	600A			t_{on}=2μs, t_f=3μs t_{stg}=8μs							156	ダーリントン
	〃 699	〃	〃	〃	300	200	30A	250W (Tc=25°C)	150	600	200	1000	5	10A			t_{on}=1.2μs, t_f=3.5μs t_{stg}=8μs							266	ダーリントン
	〃 700	〃	〃	〃	300	200	200A	770W (Tc=25°C)	125	1mA	300	>150	5	200A			t_{on}<2.5μs, t_f<12μs t_{stg}<10μs							158	ダーリントン
★	〃 701	〃																							
★	〃 702	〃	SW	Si.TMe	400	300	40A	300W (Tc=25°C)	150	1mA	400	>10	5	30A			t_{on}=1.2μs, t_f=0.8μs t_{stg}=4μs					400		266	
★	〃 703	〃	〃	〃	200	150	30A	300W (Tc=25°C)	150	600	150	>150	5	30A			t_{on}=1μs, t_f=3.5μs t_{stg}=7μs					450		266	ダーリントン
★	〃 704	三菱	〃	Si.EP	50	40	5 A	40W (Tc=25°C)	150	30	50	90~500	1	1 A	10	−500	t_{on}=1μs, t_f=1μs t_{stg}=1.5μs				10 *			301B	
	〃 705	富士電機	〃	Si.TP	600	400	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	450	300	1.5	6 A			t_{on}<3μs, t_f<15μs t_{stg}<17μs							102	ダーリントン
	〃 706	〃	〃	〃	350	350	6 A	100W (Tc=25°C)	150	1mA	345	1000	1.5	4 A			t_{on}<1μs, t_f<6μs t_{stg}<12μs							102	ダーリントン
	〃 707	〃	PA.SW	〃	500	350	8 A	100W (Tc=25°C)	150	500	500	>200	2	4 A			t_{on}<1.4μs, t_f<6μs t_{stg}<15μs							102	ダーリントン
	〃 708	〃	〃	〃	345	345	6 A	30W (Tc=25°C)	150	1mA	345	1000	1.5	4 A			t_{on}<1μs, t_f<6μs t_{stg}<12μs							322	ダーリントン
	〃 709	〃	〃	〃	250	200	4 A	25W (Tc=25°C)	150	1 mA	250	>1500	2	2 A			t_{on}<1.7μs, t_f<18μs t_{stg}<15μs							322	ダーリントン
	〃 710	〃	〃	〃	300	250	15A	150W (Tc=25°C)	150	50	300	500	2	12A			t_{on}<5μs, t_f<4μs t_{stg}<12μs							102	ダーリントン
	〃 711	〃	〃	〃	500	450	15A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	500	>100	1.5	10A			t_{on}<5μs, t_f<10μs t_{stg}<15μs							102	ダーリントン ○
★	〃 712	三菱	PA	Si.EP	100	100	4 A	30W (Tc=25°C)	150	30	100	55~300	5	500	10	−500					8 *	45		301B	2SB682とコンプリ ○
★	〃 713	〃	〃	〃	100	100	5 A	40W (Tc=25°C)	150	30	100	55~300	5	1 A	10	−500					8 *	75		301B	2SB683とコンプリ
★	〃 714	〃																							
★	〃 715	〃	PA	Si.EP	110	110	7 A	80W (Tc=25°C)	150	100	110	2000~24000	4	1 A	10	−500					30 *			341	ダーリントン
	〃 716	東芝	〃	Si.T	100	100	6 A	60W (Tc=25°C)	150	10	100	55~160	5	1 A	5	−1A					12 *	100		179	2SB686とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD717	東芝	SW	Si.T	70	50	10A	80W (Tc=25°C)	150	10	70	70~240	1	1A	4	−1A	t_{on}=0.3μs, t_{stg}=2.5μs		t_f=0.4μs		10 *	350		179	
〃 718	〃	PA	〃	120	120	8A	80W (Tc=25°C)	150	10	120	55~160	5	1A	5	−1A					12 *	170		179	2SB688 とコンプリ
★ 〃 719																								
★ 〃 720	三菱	SW	Si.T	400	400	7A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	700	2	4.5A										102	ダーリントン
〃 721	サンケン	PA	Si.DJ	100	80	6A	50W (Tc=25°C)	150	100	100	1000	4	7A										298	ダーリントン
〃 722	〃	〃	〃	120	100	6A	50W (Tc=25°C)	150	100	120	1000	4	7A										298	ダーリントン
★ 〃 723	日立	〃	Si.T	100	100	4A	40W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} 100μA	V_{CE} 80V	50~250	4	500										268	
★ 〃 724	〃	〃	〃	200	80	4A	30W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 100μA	V_{CE} 150V	>20	5	4A			t_f<1μs							268	
〃 725	〃	SW	〃	1500	600	6A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CBX} 1mA	1500	>5	5	5A			t_f<2μs							102	水平偏向用
★ 〃 726	〃	PA	〃	100	80	4A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	35~320	5	1A	5	−500					10 *	40		268	2SB690 とコンプリ
★ 〃 727	松下	〃	Si.EMe	130	80	5A	60W (Tc=25°C)	150	50	80	60~200	5	1A	5	−500					7 *	110		365	2SB691 とコンプリ
★ 〃 728	〃	〃	〃	150	100	6A	70W (Tc=25°C)	150	50	100	100	5	1A	5	−500					7 *	160		365	2SB692 とコンプリ
〃 729	日立	PA.SW	Si.E	100	100	20A	125W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} 1	80	1000~20000	3	10A			t_{on}=2μs, t_{off}=8μs							102	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 730	〃	〃	〃	100	100	25A	125W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} 1	V_{CE} 80	1000~20000	3	12A			t_{on}=2μs, t_{off}=8μs							102	ダーリントン ダンパ内蔵
★ 〃 731	松下	PA	Si.EMe	170	120	7A	80W (Tc=25°C)	150	50	120	100	5	1A	5	−500					7 *	180		365	2SB695 とコンプリ
★ 〃 732	三洋	〃	〃	150	120	8A	80W (Tc=25°C)	150	100	80	40~320	5	1A	5	−1A					15 *			102	2SB696 とコンプリ
★ 〃 733	〃	〃	〃	160	140	12A	100W (Tc=25°C)	150	100	80	40~320	5	1A	5	−1A					15 *			102	2SB697 とコンプリ
〃 734	〃	PA.SW	Si.EP	25	20	700	600	150	1	20	60~560	2	50	10	−50					250 *	8		138	2SB698 とコンプリ
★ 〃 735	日立	PA	Si.T	160	120	12A	100W (Tc=25°C)	150	1mA	120	35~200	5	1A										332	2SB699 とコンプリ
★ 〃 736	〃	〃	〃	160	140	12A	100W (Tc=25°C)	150	1mA	120	60~200	5	1A										332	2SB700 とコンプリ ○
★ 〃 737	〃	〃	〃	160	160	12A	120W (Tc=25°C)	150	1mA	140	120	5	1A										332	
★ 〃 738	〃	〃	〃	160	160	12A	125W (Tc=25°C)	150	1mA	140	60~200	5	1A										332	2SB702 とコンプリ ○
★ 〃 739																								
★ 〃 740																								
〃 741	日電	SW	Si.E	40	20	5A	15W (Tc=25°C)	150	1	40	250	2	500	5	−100		t_{on}=1.5μs t_{off}=0.4μs			200 *	50		225	
★ 〃 742	〃																							
〃 743	〃	PA.SW	Si.T	100	80	4A	40W (Tc=25°C)	150	10	80	100	5	500	5	−100					17 *	80		268	2SB703 とコンプリ ○
★ 〃 744	〃																							
★ 〃 745	〃	PA	Si.T	140	140	10A	120W (Tc=25°C)	150	50	140	80	5	2A	5	−200					15 *	270		340	2SB705 とコンプリ ○
★ 〃 746	〃	〃	〃	180	180	10A	200W (Tc=25°C)	150	50	180	80	5	2A	5	−200					15 *	300		265	2SB706 とコンプリ ○

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SD747	三菱	PA	Si. EP	50	30	500	1 W (Tc=25°C)	200	0.01	30	150	10	1				$t_{on}+t_{off}<1\ \mu s$						49B		
	〃 748	日立	〃	Si. T	250	200	3 A	80W (Tc=25°C)	150	10	200	25～200	5	1 A										102		○
★	〃 749	松下	〃	Si.TMe	750	300	3 A	50W (Tc=25°C)	150	500	750	30	5	1 A										102		
★	〃 750	〃	〃	Si. DJ	110	80	15A	100W (Tc=25°C)	150	30	40	>40	40	1 A	10	−500					1 *			102		
★	〃 751	〃	〃	Si.TP	200	140	9 A	100W (Tc=25°C)	150	50	140	100	5	1 A	5	−500					7 *	220		365	2SB713 とコンプリ	
★	〃 752	日立	〃	Si. T	160	160	15A	150W (Tc=25°C)	150	1mA	140	100	5	1 A										102		
★	〃 753	〃	〃	〃	200	200	15A	150W (Tc=25°C)	150	1mA	160	35～200	5	1 A										102	2SB723 とコンプリ	
★	〃 754	〃	〃	Si. E	25	20	700	625	150	0.1	20	100～320	1	350	1	−150					280 *	12	$C_c r_{bb'}$ 12ps	138D	2SB721 とコンプリ	
	〃 755	〃	〃	〃	100	100	50	750	150	0.5	80	250～1200	12	2	12	−5					350 *	1.6		251	2SB715 とコンプリ	
	〃 756	〃	〃	〃	120	120	50	750	150	0.5	80	250～800	12	2	12	−5					350 *	1.6		251	2SB716 とコンプリ	○
	〃 757	〃	PA	〃	160	160	50	1.25W	150	10	140	60～320	5	10	5	−10					140 *	3.8		234	2SB717 とコンプリ	
	〃 758	〃	〃	〃	200	200	50	1.25W	150	10	160	60～320	5	10	5	−10					140 *	3.8		234	2SB718 とコンプリ	
★	〃 759	〃	〃	〃	160	160	2 A	25W (Tc=25°C)	150	10	140	35～320	5	150	5	−150					100 *	20		268	2SB719 とコンプリ	
★	〃 760	〃	〃	〃	200	200	2 A	25W (Tc=25°C)	150	10	160	35～200	5	150	5	−150					100 *	20		268	2SB720 とコンプリ	
	〃 761	三洋	〃	Si.TP	180	180	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	10	80	40～200	5	300										300		
	〃 762	松下	〃	Si. T	60	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	80	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$ 25kHz			268		○
	〃 763	日立	SW	Si. E	120	60	1 A	900	150	1	100	150	5	1 A			$t_f=0.3\mu s$							251	水平偏向用	
	〃 764	〃	〃	Si. T	1500	600	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	600	20	5	100			$t_f<1.5\mu s$							102	水平偏向用	
★	〃 765	〃	〃	〃	1500	800	3 A	50W (Tc=25°C)	150	10	600	10	5	300			$t_f<1\mu s$							102	水平偏向用	
★	〃 766	松下	PA	Si.TMe	300	300R	700	30W (Tc=25°C)	150	5mA	300	60～330	5	100	10	−100					45 *			153		
★	〃 767	〃	AF	Si. EP	60	60	100	400	150	1	10	90～650	10	2	10	−2					150 *	3.5		138	2SB725 とコンプ	
	〃 768	日立	SW	Si. E	120	120	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	120	1000～20000	3	3 A										268	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 769	松下	AF	Si.EP	20	15	500	400	125	1	10	200	10	150										138		
	〃 770	〃	〃	〃	50	40	500	400	125	1	10	200	10	150										138		
	〃 771	〃	AF.LN	〃	25	25	50	150	125	1	10	450	5	2	10	−1	360	28k	1.6	15	NF= 6 dB (10V,1mA,f=1kHz)			138		
★	〃 772	〃	PA	Si.TP	150	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	150	>14	4	5 A	10	−500		$t_f<1\ \mu s$			40 *			268		○
	〃 773	日電	〃	Si. E	20	16	2 A	1 W	150	0.1	16	250	2	100	2	−10					110 *	16		278	2SB733 とコンプリ	
	〃 774	〃	〃	〃	100	50	1 A	1 W	150	0.1	50	300	2	100	2	−10					95 *	16		278	2SB734 とコンプリ	
★	〃 775	〃																								
★	〃 776	東芝	PA	Si.TMe	200	180	5 A	100W (Tc=25°C)	150	100	200	500～2000	5	1 A										102		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	r_{bb} h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SD777	東芝	PA	Si 二重拡散	55±10	55±10	4 A	100W (Tc=25°C)	150	100	40	1000	5	500			許容エネルギー E_T>100Wsec							102		
★	〃 778	松下	AF	Si.EP	30	25	100	400	135			90~650	5	2										151		
★	〃 779	〃	〃	〃	45	45	50	400	135			90~650	5	2										151		
	〃 780	日電	〃	Si.E	60	60	300	200	150	0.1	60	200	1	50	6	−10					140 *	7		176	2SB736 とコンプリ	○
	〃 781	日立	SW	Si.EP	150	60	2 A	1 W	150	1	100	150	5	1.5A			t_f=0.35μs							160		
★	〃 782	〃	〃	Si 二重拡散	300	80	5 A	30W (Tc=25°C)	150	5 mA	300	80	5	300			t_f< 1 μs							268	水平偏向用	
★	〃 783	〃	〃	〃	1500	600	4 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CBX} 500	1500	15	5	300			t_f< 2 μs							102	水平偏向用	
	〃 784	〃	〃	〃	1700	700	5 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CBX} 1 mA	1700	10	5	100			t_f< 2 μs							102	水平偏向用	
	〃 785	〃	〃	Si.T	1900	700	5 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CBX} 1 mA	1900	10	5	100			t_f< 2 μs							102	水平偏向用	
	〃 786	ローム	AF.LN	Si.EP	50	40	300	250	125	0.5	30	120~560	6	10	6	−10	V_{NO}<150mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				100 *		4	138	2SB737 とコンプリ	
	〃 787	日立	PA	Si.E	20	16	2 A	900	150	2	16	100~800	2	100	2	−10					100 *	20		251	2SB738 とコンプリ	
	〃 788	〃	〃	〃	20	20	2 A	900	150	2	16	100~800	2	100	2	−10					100 *	20		251	2SB739 とコンプリ	
	〃 789	〃	〃	〃	100	50	1 A	900	150	1	80	100~800	2	100	2	−10					100 *	20		251	2SB740 とコンプリ	
★	〃 790	〃	〃	〃	100	70	1 A	900	150	1	80	100~320	2	100	2	−10					80 *	20		251	2SB741 とコンプリ	
★	〃 791	ソニー																								
★	〃 792	松下	SW	Si.TMe	1500	1500S	5 A	35W (Tc=90°C)	130	50	750	> 4	10	4 A			t_f<0.7μs							102	水平偏向用	
★	〃 793	日電	PA.SW	Si.E	40	30	3 A	10W (Tc=25°C)	150	1	30	100	5	1 A	5	−100					65 *	55		225	2SB743 とコンプリ	
	〃 794	〃	〃	〃	70	45	3 A	10W (Tc=25°C)	150	1	45	100	5	500	5	−100					60 *	40		225	2SB744 とコンプリ	○
	〃 795	〃	〃	〃	50	40	3 A	20W (Tc=25°C)	150	1	50	160	1	500	5	−100					95 *	40		268		○
	〃 796	富士電機	SW.PA	Si.TP	500	450	8 A	100W (Tc=25°C)	150	500	500	>200	2	4 A				t_{on}<1.4μs, t_f< 6 μs t_{stg}<15μs						102	ダーリントン	
	〃 797	東芝	PA.SW	Si.T	100	80	30A	200W (Tc=25°C)	175	100	100	60~200	5	1 A	5	−1A		t_{on}=1.5μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 6 μs			3 *	400		102		
	〃 798	〃	〃	〃	600	300	6 A	30W (Tc=25°C)	150	500	600	>1500	2	2 A				t_{on}= 1 μs, t_f= 5 μs t_{stg}= 8 μs				35		268	ダーリントン	
	〃 799	〃	〃	〃	600	400	6 A	30W (Tc=25°C)	150	500	600	>600	2	2 A				t_{on}= 1 μs, t_f= 5 μs t_{stg}= 8 μs				35		268	ダーリントン	
★	〃 800	日立	SW	〃	750	300	4 A	30W (Tc=25°C)	125	I_{CES} 500	750	15~60	5	1 A	10	−200		t_f=0.15μs t_{stg}=1.2μs			8 *	85		102		
	〃 801	〃	〃	〃	800	375	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	800	3.5~12	5	4 A				t_f<0.5μs						102		
	〃 802	〃	〃	〃	900	400	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	900	3.5~12	5	4 A				t_f<0.5μs						102		
★	〃 803	松下	PA	Si.DJ	120	100	8 A	100W (Tc=25°C)	150	100	120	>2000	4	1 A				h_{FE}> 7 (V_{CE}= 4 V, I_C=40A)						102	ダーリントン ダンパ内蔵	
★	〃 804	〃	〃	Si.TMe	60	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	30~160	3	1 A	10	−200					$f_{\alpha e}$ 70kHz			268		
	〃 805	富士電機	SW	Si.TP	600	600	30A	200W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	>100	5	30A				t_{on}< 3 μs, t_f< 4 μs t_{stg}<12μs						266	ダーリントン	
	〃 806	〃	〃	〃	600	600	50A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	>100	5	50A				t_{on}< 3 μs, t_f< 4 μs t_{stg}<12μs						254	ダーリントン	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SD807	サンケン	SW	Si.TMe	1000	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1000	11	4	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f<2.5μs t_{stg}< 8 μs							102		
★	〃 808	日立	RF	Si.EP	25	20	500	400	150	0.2	18	120	1	50	1	−50					250 *	3.2	$C_{r\,rbb'}$ 12ps	138		
	〃 809	日電	PA.SW	Si.E	100	50	1 A	10W (Tc=25°C)	150	0.1	50	250	2	100	2	−10					85 *	15		225	2SB731とコンプリ	
	〃 810	サンケン	PA	Si.EMe	20	20	4 A	30W (Tc=25°C)	150	1 mA	20	400	4	1 A										298		
	〃 811	東芝	PA.SW	Si.TMe	900	400	8 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	100	8	5	4 A										102		
	〃 812	松下	PA	Si.TP	80	80	5 A	50W (Tc=25°C)	150	50	80	90	5	1 A	5	−500					15 *	90		268	2SB747とコンプリ	
	〃 813	〃	〃	Si.EP	25	20	500	200	125	0.1	25	65~220	2	500	10	−50					150 *	6		176		
	〃 814	〃	AF.LN	〃	150	150	50	200	125	1	100	90~450	5	10	10	−10	V_{NO} = 150mV (10V, 1mA, R_G = 100kΩ, A_v = 80dB)				150 *	2.3		176		○
	〃 815	富士電機	SW	Si.TP	120	120	30A	300W (Tc=25°C)	150	1 mA	120	300	3	30A			t_{on}< 3 μs, t_f< 3 μs t_{stg}< 8 μs							266	ダーリントン	
	〃 816	〃	〃	〃	300	300	4 A	30W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	1500	2	3 A			t_{on}< 2 μs, t_f< 5 μs t_{stg}< 15 μs							268		
★	〃 817	東芝	〃	Si.TMe	1500	600	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	500										102		
	〃 818	〃	〃	〃	1500	600	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	500	10	−100	t_f< 1 μs				3 *	95		102	水平偏向用	
	〃 819	〃	〃	〃	1500	600	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	500	10	−100	t_f< 1 μs				3 *	95		102	水平偏向用	
	〃 820	〃	〃	〃	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A	10	−100	t_f< 1 μs				3 *	165		102	水平偏向用	
	〃 821	〃	〃	〃	1500	600	6 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A	10	−100	t_f< 1 μs				3 *	165		102	水平偏向用	
	〃 822	〃	〃	〃	1500	600	7 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A	10	−100	t_f< 1 μs				3 *	165		102	水平偏向用	
	〃 823	三洋	SW	Si.EP	200	90	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	>20	5	3 A	5	−1 A	t_f< 1 μs				15 *			268		
★	〃 824	日立	PA	Si.T	120	100	6 A	60W (Tc=25°C)	150	1 mA	80	100	5	1 A										332		○
★	〃 825	〃	〃	〃	120	120	7 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	100	100	5	1 A										332		○
	〃 826	三洋	SW	Si.EP	60	20	5 A	10W (Tc=25°C)	150	1	50	120~560	2	500	10	−50					120 *	45		296		
	〃 827	日立		Si.T	500	500	4 A	80W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} 1 mA	500	>500	2	4 A										332	ダーリントン ダンパ内蔵	
★	〃 828	〃	〃	〃	500	500	4 A	80W (Tc=25°C)	150	5	400	2000	2	4 A										333	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 829	〃	〃	〃	150	120	15A	100W (Tc=25°C)	150	0.1	80	4000	2	15A										332	ダーリントン ダンパ内蔵	
★	〃 830	富士通	〃	Si.P	150		5 A	30W (Tc=25°C)	150	1	100	6000	2	3 A			t_r=0.2μs, t_f= 2 μs t_{stg}= 7 μs							268	ダーリントン	
★	〃 831	〃																								
	〃 832	〃	SW	Si.EP	600	450	50A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	200	5	50A			t_{on}< 1 μs, t_f<2.5μs t_{stg}< 8 μs							228	ダーリントン	
	〃 833	富士電機	SW.PA	Si.TP	60	60	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	>2000	3	3 A										268	ダーリントン	
	〃 834	〃	〃	〃	250	200	4 A	25W (Tc=25°C)	150	100	250	>1500	2	2 A			t_{on}<1.7μs, t_f<18μs t_{stg}<15μs							268	ダーリントン	
	〃 835	〃	〃	〃	400	400	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	400	>400	1.5	4 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 6 μs t_{stg}<12μs							268	ダーリントン	
	〃 836	松下	PA	Si.EP	60	60	2 A	35W (Tc=25°C)	150	1 mA	60	1000~10000	4	1 A			t_{on}=0.4μs, t_{off}= 4 μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵	○

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SD837	松下	PA	Si.EP	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	200	60	1000～10000	3	3 A			t_{on}=0.3μs, t_{off}=4μs							268	ダーリントンダンパ内蔵	○
★	〃 838	三洋	SW	Si.T	2500	900	3 A	50W (Tc=25°C)	150	50	1000	3～15	10	1.5A			t_f< 1 μs							102	水平偏向用	
★	〃 839	三菱	〃	Si.EP	35	30	4 A	30W (Tc=25°C)	150	10	30	1000～3000	5	500			t_r= 3 μs, t_f=1.7μs t_{stg}= 2 μs							301B	ダーリントン	
★	〃 840	〃	〃	〃	70	60	5 A	40W (Tc=25°C)	150	10	60	1000～3000	5	500			t_r=1.5μs, t_f=1.5μs t_{stg}= 4 μs				27 *			301B	ダーリントン	
	〃 841	東芝	〃	Si.T	800	400	3 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	800	20	5	500	10	−100	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 7 μs				4 *	75		268		
	〃 842	〃	AF. PA. SW	〃	80	80	30A	150W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	5	20A			t_{on}< 2 μs, t_f< 5 μs t_{stg}<20μs							102	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 843	〃	PA.SW	〃	100	80	7 A	40W (Tc=25°C)	150	5	100	70～240	1	1 A	4	−1A	t_{on}=0.4μs, t_f=0.5μs t_{stg}=2.5μs				10 *	250		268	2SB753とコンプリ	
	〃 844	〃	PA	〃	50	50	7 A	60W (Tc=25°C)	150	10	50	70～240	1	1 A	5	−1A					15 *	250		179	2SB754とコンプリ	
	〃 845	〃	〃	〃	150	150	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	150	100	5	1 A								200		125	2SB755とコンプリ	
★	〃 846	〃																								
	〃 847	富士電機	SW.PA	Si.TP	40	40	15A	80W (Tc=25°C)	150	10	40	>40	5	5 A			t_{on}= 1 μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 2 μs							211	2SB757とコンプリ	
★	〃 848	日電	PA	Si.T	120	120	7 A	80W (Tc=25°C)	150	50	110	80	5	1 A										295		○
★	〃 849	松下	SW	Si.TMe	1500	600	3 A	25W (Tc=25°C)	130	100	750	7	10	3 A			t_{stg}<16μs, t_f< 1 μs							102	水平偏向用	
★	〃 850	〃	〃	〃	1500	700	3 A	25W (Tc=25°C)	130	50	750	8	10	2.5A			t_{stg}<16μs, t_f< 1 μs							102	水平偏向用	
★	〃 851	日電	PA.SW	Si.E	150	100	10A	80W (Tc=25°C)	150	10	100	3000	2	10A			t_{on}= 1 μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 2 μs							340	ダーリントン	
★	〃 852	〃	〃	〃	150	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	10	100	3000	2	15A			t_{on}= 1 μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 3 μs							340	ダーリントン	
★	〃 853	〃																								
	〃 854	三菱	PA	Si.EP	100	80	2.2A	10W (Tc=25°C)	150	0.5	50	100	5	1 A	5	−500	t_{on}< 100ns t_{off}< 500ns				100 *	30		84B		
★	〃 855	松下	〃	〃	60	60	1 A	30W (Tc=25°C)	150	200	60	120	4	200										268	2SB760とコンプリ	○
	〃 856	〃	〃	〃	60	60	3 A	35W (Tc=25°C)	150	200	60	100	4	1 A										268	2SB761とコンプリ	○
	〃 857	〃	〃	Si.TP	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	400	60	100	4	1 A										268	2SB762とコンプリ	○
	〃 858	〃	〃	〃	60	60	5 A	60W (Tc=25°C)	150	400	60	120	4	1 A										365	2SB763とコンプリ	○
	〃 859	〃	〃	〃	350	250	750	35W (Tc=25°C)	150	1 mA	350	120	10	300										268		○
	〃 860	〃	〃	〃	350	250	1 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	350	120	10	300										268		○
★	〃 861	〃	〃	〃	350	250	1.5A	45W (Tc=25°C)	150	1 mA	350	120	10	300										268		○
★	〃 862	日電	〃	Si.E	20	16	2 A	10W (Tc=25°C)	150	0.1	16	300	2	100										225		
	〃 863	三洋	AF.PA	Si.EP	60	50	1 A	900	150	1	50	60～320	2	50	10	−50					150 *	12		294	2SB764とコンプリ	
	〃 864	日立	PA.SW	Si.T	120	120	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	120	1000～20000	3	1.5A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.1μs t_{stg}=4.5μs							268	ダーリントンダンパ内蔵	
	〃 865	富士電機	SW	〃	300	300	4 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	1500	2	3 A			t_{on}< 2 μs, t_f< 5 μs t_{stg}<15μs							322	ダーリントン	
	〃 866	松下	〃	Si.EP	130	80	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	60～260	2	3 A	10	−500		t_f=0.1μs			30 *			268		○

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μS)	f_{ab} / f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD867	東芝	PA.SW	Si.T	130	110	10A	100W (Tc=25°C)	175	100	130	50~200	5	1A	5	−1A	t_{on}=1.5μs, t_f=1.2μs t_{stg}=4.5μs				3 *	200		102	
〃 868	〃	SW	Si.TMe	1500	600	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	500	10	−100	t_f<1μs				3 *	95		102	水平偏向用
〃 869	〃	〃	〃	1500	600	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	500	10	−100	t_f<1μs				3 *	95		102	水平偏向用
〃 870	〃	〃	〃	1500	600	5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	1A	10	−100	t_f<1μs				3 *	165		102	水平偏向用
〃 871	〃	〃	〃	1500	600	6A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	1A	10	−100	t_f<1μs				3 *	165		102	水平偏向用
★ 〃 872	三菱	SW	Si.TP	500	400	5A	40W (Tc=25°C)	150	30	450	20~45	5	1A			t_r<1μs, t_f<1μs t_{stg}<2μs							301B	
〃 873	東芝	PA.SW	Si.T	160	140	16A	150W (Tc=25°C)	175	100	140	15~60	4	8A	4	−1A	t_{on}=1.5μs, t_f=1μs t_{stg}=6μs				3 *	350		102	2N3773 相当
〃 874	松下	PA	Si.EP	30	25	1A	500	125	0.1	20	160	10	500	10	−50					200 *	15		336	2SB766 とコンプリ ○
〃 875	〃	〃	〃	80	80	500	500	125	0.1	20	160	10	150	10	−50					120 *	11		336	2SB767 とコンプリ
〃 876	〃	〃	Si.TP	200	150	1A	40W (Tc=25°C)	150	100	200	500~2000	4	200	4	−100					25 *			268	
〃 877	東芝	PA.SW	Si.T	110	80	3A	25W (Tc=25°C)	175	100	110	60~300	5	500	5	−500	t_{on}=1.5μs, t_f=2μs t_{stg}=5μs				3 *	85		99	
〃 878	〃	〃	〃	100	60	15A	115W (Tc=25°C)	175	100	100	20~70	4	4A	4	−1A	t_{on}=2μs, t_f=1μs t_{stg}=3.5μs				3 *	150		102	2N3055 相当
〃 879	三洋	SW	Si.EP	30	10	3A	750	150	1	20	210	2	3A	10	−50					200 *	30		138	2SB893 とコンプリ
〃 880	東芝	PA	Si.T	60	60	3A	30W (Tc=25°C)	150	100	60	60~300	5	500	5	−500	t_{on}=0.8μs, t_f=0.8μs t_{stg}=1.5μs				3 *	70		268	2SB834 とコンプリ
★ 〃 881	日電																							
〃 882	〃	PA.SW	Si.E	40	30	3A	10W (Tc=25°C)	150	1	30	160	2	1A	5	−100					90 *	45		225	2SB772 とコンプリ
★ 〃 883	〃	PA	Si.T	100	100	6A	70W (Tc=25°C)	150	50	90	80	5	1A										295	○
★ 〃 884	松下	SW	Si.TP	330	200	7A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	330	25	4	5A			t_{stg}<2μs, t_f<1μs							268	水平偏向用
★ 〃 885	〃	〃	〃	330	330	7A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	330	25	4	5A			t_{stg}<2μs, t_f<1μs							268	
〃 886	〃	PA	〃	80	60	3A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	500~1500	4	500	12	−200					50 *			268	
〃 887	〃	〃	〃	80	60	4A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	1000	4	1A										268	
〃 888	〃	〃	〃	80	60	6A	50W (Tc=25°C)	150	100	80	1000	4	1A										268	
〃 889	〃	AF	Si.EP	30	25	100	400	150	1	10	120~650	10	2	10	−2					150 *	3		138	2SB774 とコンプリ
★ 〃 890	〃	〃	〃	100	100	20	400	150	1	10	300	10	2	10	−2					150 *	3		138	
〃 891	〃	〃	〃	30	25	200	250	150	0.1	25	2000~20000	10	200										138	ダーリントン ○
〃 892	〃	〃	〃	30	25	500	400	150	0.1	25	2000~20000	10	500										138	ダーリントン ○
〃 893	〃	〃	〃	30	25	1A	750	150	0.1	25	2000~20000	10	1A										138	ダーリントン ○
〃 894	三洋	AF.PA	〃	30	25	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	1	20	>4000	2	500	10	−50					120 *			296	ダーリントン
〃 895	〃	PA.SW	Si.P	100	85	6A	60W (Tc=25°C)	150	100	40	60~200	5	1A	5	−1A					10 *	110		346	2SB775 とコンプリ
〃 896	〃	〃	〃	120	100	7A	70W (Tc=25°C)	150	100	80	60~200	5	1A	5	−1A					10 *	140		346	2SB776 とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SD897	日立	SW	Si.T	1500	1500S	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1500	8	5	300			t_f<1.2μs							102	水平偏向用 ダンパ内蔵	○
	〃 898	〃	〃	〃	1500	1500S	3 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1500						t_f< 1 μs							102	水平偏向用 ダンパ内蔵	○
★	〃 899	〃	〃	〃	1500	1500S	4 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1500						t_f<1.2μs							102	水平偏向用 ダンパ内蔵	○
	〃 900	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1500						t_f<1.5μs							102	水平偏向用 ダンパ内蔵	○
	〃 901	日電	PA	〃	200	150	2 A	25W (Tc=25°C)	150	50	150	100	10	400										268		
★	〃 902	三洋	〃	Si.TP	350	300	4 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	100	15	500										102		
★	〃 903	〃	SW	Si.TMe	1500	600	7 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1500	5~11.5	5	4 A			t_f< 1 μs							102	ダンパ内蔵	
★	〃 904	〃	〃	〃	1500	600	7 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 1 mA	1500	4 ~10	5	3 A			t_f< 1 μs							102	水平偏向用	
	〃 905	日立	〃	Si.T	1400	650	8 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1400	20	5	1 A			t_f< 1 μs							102	水平偏向用	
	〃 906	〃	〃	〃	1400	650	8 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1400	17	5	1 A			t_f< 1 μs							102	水平偏向用	
	〃 907	富士電機	AF. PA	Si. TP	80	80	10A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	80	120	5	2 A										211		
	〃 908	〃	〃	〃	120	120	10A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	120	120	5	2 A										211		
	〃 909	〃	〃	〃	150	80	15A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	80	120	5	2 A										211		
	〃 910	〃	〃	〃	120	120	15A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	120	120	5	2 A										211		
	〃 911	〃	PA	〃	150	80	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	80	120	5	2 A										102		
	〃 912	〃	〃	〃	120	120	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	120	120	5	2 A										102		
	〃 913	〃	SW	〃	200	80	25A	150W (Tc=25°C)	150	100	200	>20	5	25A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.4μs t_{stg}<2.5μs							103		
	〃 914	〃	〃	〃	200	120	25A	150W (Tc=25°C)	150	100	200	>20	5	25A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.4μs t_{stg}<2.5μs							103		
	〃 915	〃	〃	〃	600	600	30A	200W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	300	5	30A			t_{on}< 3 μs, t_f< 4 μs t_{stg}<12μs							318	ターリンドン	
	〃 916	〃	SW.PA	〃	60	60	7 A	30W (Tc=25°C)	150	100	60	>800	1.5A	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 5 μs							268	ターリンドン	
	〃 917	松下	SW	〃	330	200	7 A	70W (Tc=25°C)	150	100mA	330	30	4	5 A			t_{stg}< 2 μs, t_f<0.75μs							365		
★	〃 918	日電	PA	Si. T	250	250	2 A	80W (Tc=25°C)	150	100	200	100	10	500										295		
★	〃 919	松下	AF	Si.EP	30	25	500	400	125	0.1	20	85~340	10	150	10	−50					200*	6		276	2SB780 とコンー	
	〃 920	富士電機	PA	Si.TP	200	180	5 A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	>700	4	1 A	12	−500					25*	35		102		
	〃 921	〃	〃	〃	200	180	5 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	>700	4	1 A	12	−500					25*	35		211		
	〃 922	〃	〃	〃	150	100	10A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	150	>700	4	3 A	12	−500					25*	45		102		
	〃 923	〃	〃	〃	150	100	10A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	150	>700	4	1 A	12	−500					25*	45		211		
★	〃 924	日立																								
★	〃 925	〃																								
★	〃 926	〃	AF. PA	Si. T	50	50	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	50	100	5	500										268		

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SD927	日立	AF. PA	Si. T	60	60	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	50	100	5	500										268	
★	〃 928	〃	〃	〃	80	80	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	50	100	5	500										268	
	〃 929	富士電機	PA	Si. TP	200	180	5 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	>700	4	1 A										102	
	〃 930	〃	AF. PA	〃	200	180	5 A	30W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	5000	4	700										268	ダーリントン
	〃 931	〃	PA	〃	200	180	5 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	>700	4	1 A										102	
★	〃 932	日立	〃	Si. T	500	300	6 A	80W (Tc=25°C)	150	100	500	1500	2	4 A										332	ダーリントン
	〃 933	〃	〃	〃	300	300	6 A	80W (Tc=25°C)	150	100	300	1500	2	4 A										102	ダーリントン ダンパ内蔵
	〃 934	〃	〃	〃	300	300	6 A	80W (Tc=25°C)	150	100	300	1500	2	4 A										332	ダーリントン ダンパ内蔵
	〃 935	松下	〃	Si. TP	250	100	5 A	60W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	100	4	1 A										365	
★	〃 936	東芝	SW	Si. TMe	300	450	+30A −47A	400W (Tc=25°C)	150	600	300	>150	5	30A			t_{on} = 1 μs, t_f = 2.5 μs t_{stg} = 10 μs							319	
★	〃 937	〃	〃	〃	400	350	+30A −47A	400W (Tc=25°C)	150	600	400	>150	5	30A			t_{on} = 1 μs, t_f = 2.5 μs t_{stg} = 10 μs							319	
★	〃 938	〃	〃	〃	600	250	+30A −47A	400W (Tc=25°C)	150	600	600	>150	5	30A			t_{on} = 1 μs, t_f = 2.5 μs t_{stg} = 10 μs							319	
★	〃 939	〃	〃	〃	300	450	+40A −47A	400W (Tc=25°C)	150	800	300	>150	5	40A			t_{on} = 1 μs, t_f = 2.5 μs t_{stg} = 10 μs							319	
★	〃 940	〃	〃	〃	400	350	+40A −47A	400W (Tc=25°C)	150	800	400	>150	5	40A			t_{on} = 1 μs, t_f = 2.5 μs t_{stg} = 10 μs							319	
★	〃 941	〃	〃	〃	600	250	+40A −47A	400W (Tc=25°C)	150	800	600	>150	5	40A			t_{on} = 1 μs, t_f = 2.5 μs t_{stg} = 10 μs							319	
★	〃 942	〃	〃	〃	300	350	+50A −47A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	>150	5	50A			t_{on} = 1 μs, t_f = 2.5 μs t_{stg} = 8 μs							319	
★	〃 943	〃	〃	〃	400	250	+50A −47A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	400	>150	5	50A			t_{on} = 1 μs, t_f = 2.5 μs t_{stg} = 8 μs							319	
★	〃 944	ローム		Si. EP	40	40	2 A	5 W (Tc=25°C)				>4000									150 *			232	2SB786 とコンプリ
★	〃 945																								
	〃 946	松下	AF	Si. EP	30	25	1 A	1.2W	150	0.1	25	2000～20000	10	1 A										222	ダーリントン ○
	〃 947	ローム	AF. PA	〃	40	40R	2 A	5 W (Tc=25°C)	150	1	24	20000	3	500	6	−100					150 *	11		74	ダーリントン
	〃 948	松下	SW	Si. TMe	1600	1600S	1 A	25W (Tc=25°C)	130	10	750	4	5	1 A			t_{stg}<12μs, t_f<1.2μs							153	水平偏向用
	〃 949	〃	〃	〃	1500	1500S	2 A	40W (Tc=25°C)	130	50	750	4	5	2 A			t_{stg}<13μs, t_f<1.2μs							102	水平偏向用
★	〃 950	〃	〃	〃	1500	1500S	I_{cp} 4.5A	42W (Tc=25°C)	130	50	750	3～8	10	2 A			t_f<0.9μs							102	水平偏向用 ダンパ内蔵
★	〃 951	〃	〃	〃	1500	1500S	I_{cp} 5 A	65W (Tc=25°C)	130	50	750	3～12	10	2.5A			t_f<0.9μs							102	水平偏向用 ダンパ内蔵
	〃 952	〃	〃	〃	1500	1500S	I_{cp} 5 A	70W (Tc=25°C)	130			4～12					t_f<0.9μs							102	水平偏向用 ダンパ内蔵
★	〃 953	〃	〃	〃	1500	1500S	I_{cp} 7 A	95W (Tc=25°C)	130	100	750	3～8	10	4 A			t_f<0.8μs							102	ダンパ内蔵
	〃 954	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	95W (Tc=25°C)	130	50	750	7	10	4 A			t_{stg}<16μs, t_f< 1 μs							102	水平偏向用
★	〃 955	日立	AF	Si. E	120	80	50	625	150	10	120	120	5	10										138D	
	〃 956	〃	SW	Si. T	1500	1500S	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1500						t_f< 1 μs							102	水平偏向用 ダンパ内蔵

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
	2SD957	日立	SW	Si. T	1500	1500S	6 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1500						t_f<1.5μs							102	水平偏向用 ダンパ内蔵	○
	〃 958	松下	AF. LN	Si. EP	120	120	20	400	150	0.1	50	180~1040	5	2										151	2SB788 とコンプリ	
	〃 959	〃	SW	〃	130	80	4 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	60~260	2	500	10	−500		t_f=0.15μs			30 *			268	2SB867 とコンプリ	
	〃 960	〃	〃	〃	130	80	4 A	35W (Tc=25°C)	150	10	100	60~260	2	1 A	10	−500		t_f=0.15μs			30 *			268	2SB868 とコンプリ	
	〃 961	〃	〃	〃	130	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	60~260	2	2 A	10	−500		t_f=0.15μs			30 *			268	2SB869 とコンプリ	
	〃 962	サンケン	PA	Si. TP	200	200	5 A	80W (Tc=25°C)	150	100	200	3000	4	1 A										102	ダーリントン	
	〃 963	〃	〃	〃	200	200	5 A	100W (Tc=25°C)	150	100	200	3000	4	1 A										102	ダーリントン	
★	〃 964	三菱																								
	〃 965	松下	AF	Si. EP	40	20	5 A	750	150	0.1	10	180~600	2	500	6	−50					150 *	30		138		
	〃 966	〃	〃	〃	40	20	5 A	1 W	150	0.1	10	180~600	2	500	6	−50					150 *	30		294	2SB873 とコンプリ	
	〃 967	〃	〃	〃	30	25	200	400	135	0.1	25	7000	10	200										151	ダーリントン	
	〃 968	〃	〃	〃	100	100	500	1 W (プリント基板使用)	150			65~330	10	150	10	−50					120 *	11		336	2SB789 とコンプリ	○
	〃 969	〃	〃	〃	25	20	500	600	135	0.1	25	65~220	2	500	10	−50					150 *	6		151	2SB790 とコンプリ	
	〃 970	日立	SW	Si. T	120	120	8 A	50W (Tc=25°C)	150	100	120	1000~20000	3	4 A			t_{on}=0.4μs, t_f=1.1μs t_{stg}=5.4μs							268	2SB791 とコンプリ	
★	〃 971	サンケン	PA	Si. TP	300	300	6 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	2000	2	2 A										298	ダーリントン	
★	〃 972	〃	〃	〃	50	50	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	50	3000	4	3 A										298	ダーリントン	
★	〃 973	松下	AF	Si. EP	30	25	1 A	1 W	150	0.1	20	60~340	10	500	10	−50					200 *	11		151	2SB793 とコンプリ	○
	〃 974	日立	SW	Si. E	120	60	1 A	900	150	1	100	>150	5	1 A			t_f=0.4μs							251	水平偏向用	
	〃 975	〃	〃	〃	150	60	2 A	1 W	150	1	100	>150	5	1.5A			t_f<0.6μs							160	水平偏向用	
★	〃 976	〃	〃	Si. T	300	120	7 A	50W (Tc=25°C)	150	5 mA	300	>25	5	5 A			t_f<0.5μs							268	水平偏向用	○
★	〃 977	三洋	〃	Si. TP	450	350	4 A	40W (Tc=25°C)	150	500	450	300	1.5	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 5 μs t_{stg}<20μs							267	ダーリントン	
★	〃 978	〃	〃	〃	450	350	5 A	40W (Tc=25°C)	150	500	450	300	1.5	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 5 μs t_{stg}<20μs							268	ダーリントン	
★	〃 979	〃	〃	〃	450	350	10A	100W (Tc=25°C)	150	500	450	900	2.4	3.6A			t_{on}< 1 μs, t_f< 5 μs t_{stg}<20μs							346		
★	〃 980	〃	〃	〃	450	350	7 A	100W (Tc=25°C)	150	500	450	900	2.4	3.6A			t_{on}< 1 μs, t_f< 5 μs t_{stg}<20μs							346		
	〃 981	富士電機	PA	〃	200	180	5 A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	3000	4	1 A	12	−500					25 *	35		102	ダーリントン	
	〃 982	〃	〃	〃	200	180	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	3000	4	1 A	12	−500					25 *	35		268	ダーリントン	
	〃 983	〃	〃	〃	150	100	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	150	3000	4	1 A	12	−500					25 *	35		268	ダーリントン	
★	〃 984																									
	〃 985	日電	PA. SW	Si. E	150	60	±1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	60	2000~30000	2	1 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.5μs t_{stg}= 1 μs							225	ダンパ内蔵 ダーリントン	
	〃 986	〃	〃	〃	150	80	±1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	80	2000~30000	2	1 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.5μs t_{stg}= 1 μs							225	ダンパ内蔵 ダーリントン	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SD987	日電	SW	Si. T	500	400	±5A	40W (Tc=25°C)	150	10	400	>100	2	3 A			t_{on} = 1 μs, t_f = 4 μs t_{stg} = 9 μs							268	ダンパ内蔵ダーリントン
★	〃 988	〃																							
★	〃 989	〃																							
★	〃 990	日立	SW	Si. T	100	80	3 A	30W (Tc=25°C)	150	10	80	>500	4	500	12	−200					80 *			268	
	〃 991	〃	〃	〃	300	300	6 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} 100	300	>500	2	4 A			t_{on} = 2 μs, t_{off} = 23μs							268	ダンパ内蔵
	〃 992	日電	PA. SW	Si. E	30	30	2 A	10W (Tc=25°C)	150	10	20	35~200	0.5	100										186	
★	〃 993	三洋	SW	Si.TMe	1500	600	3 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1500	10	5	2 A				t_f < 1 μs						102	水平偏向用
★	〃 994	〃	〃	〃	1500	600	8 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1000	10	5	5 A				t_f < 1 μs						102	水平偏向用
★	〃 995	〃	〃	〃	2500	900	3 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	2500	10	10	1.5A				t_f < 1 μs						102	水平偏向用
★	〃 996	東芝																							
★	〃 997	日電	PA	Si. T	250	200	10A	200W (Tc=25°C)	150	50	200	80	5	2 A	5	−200					15 *	300		102	2SB796 とコンプリ
	〃 998	〃	〃	Si. E	100	60	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	60	7000	2	500										225	ダーリントン
	〃 999	〃	〃	〃	30	25	1 A	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	30	200	1	100	6	−10					130 *	22		336	2SB798 とコンプリ
	〃 1000	〃	〃	〃	60	50	700	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	60	200	1	100	6	−10					110 *	13		336	2SB799 とコンプリ
	〃 1001	〃	AF	〃	80	80	300	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	80	200	1	50	6	−10					140 *	7		336	2SB800 とコンプリ
	〃 1002	〃	〃	〃	45	45	1 A	400	150	0.1	30	100	2	150	10	−10					160 *	12		336	
	〃 1003	〃	〃	〃	60	60	1 A	400	150	0.1	30	90	2	150	10	−10					160 *	12		336	
	〃 1004	〃	〃	〃	100	80	1 A	400	150	0.1	30	90	2	150	10	−10					160 *	12		336	
	〃 1005	〃	〃	〃	100	80	1 A	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	100	160	2	100	5	−10					100 *	8		336	2SB804 とコンプリ
	〃 1006	〃	〃	〃	100	100	700	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	100	200	1	100	10	−10					90 *	12		336	2SB805 とコンプリ
	〃 1007	〃	〃	〃	120	120	700	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	120	200	1	100	10	−10					90 *	12		336	2SB806 とコンプリ
★	〃 1008	東芝																							
	〃 1009	松下	AF	Si. EP	150	150	50	1 W (プリント基板使用)	150	1	100	90~450	5	10	10	−10					150 *	2.3		336	2SB807 とコンプリ
	〃 1010	〃	〃	〃	50	40	50	300	125	0.1	20	400~2000	10	2			V_{NO} = 80mV (10V, 1mA, R_G = 100kΩ, G_V = 80dB)				120 *	2.6		138	
	〃 1011	〃	〃	〃	100	100	20	300	125	0.1	50	400~2000	10	2							100 *	2.2		138	
★	〃 1012	三洋	PA	〃	20	15	700	250	125	1	15	160~960	2	50	10	−50					250 *	8		92	2SB808 とコンプリ
★	〃 1013	三菱																							
★	〃 1014	ソニー																							
★	〃 1015	〃	SW	Si. E	140	50	2 A	900	150	2	100	150~1500	2	10		逆方向電流増幅率 h_{FER} = 150～1500 (V_{CE} = 2 V, I_E = 10mA)								294	双方向性
	〃 1016	三洋	〃	Si.TMe	1500	600	7 A	50W (Tc=25°C)	150	40	1000	7	5	4 A				t_f < 0.9μs						102	水平偏向用

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
	2SD1017	日電	PA	Si. T	250	250	2 A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	40~250	10	400										162	
	〃 1018	〃	〃	〃	250	250	4 A	80W (Tc=25°C)	150	100	200	40~250	10	500										162	
★	〃 1019	〃																							
	〃 1020	〃	AF	Si. E	30	25	700	350	150	0.1	30	200	1	100	6	−10					170*	13		42	2SB810 とコンプリ
	〃 1021	〃	PA	〃	30	25	1 A	350	150	0.1	30	200	1	100	6	−10					130*	22		42	2SB811 とコンプリ
	〃 1022	新電元	SW	Si. T	100	100	5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	100	>1500	3	3 A	10	−500	t_{on}=1 μs, t_f=1.5μs t_{stg}=2.5μs				50*			268	ダーリントン T5L10
	〃 1023	〃	PA. SW	Si. TP	200	200	5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	200	>1500	3	3 A	10	−500	t_{on}<2 μs, t_f<5 μs t_{stg}<8 μs				50*			268	ダーリントン T5L20
	〃 1024	〃	SW	Si. T	100	100	8 A	50W (Tc=25°C)	150	100	100	>1500	3	5 A	10	−800	t_{on}=1 μs, t_f=1.5μs t_{stg}=2.5μs				50*			268	ダーリントン T8L10
	〃 1025	〃	PA. SW	Si. TP	200	200	8 A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	>1500	3	5 A	10	−800	t_{on}<2 μs, t_f<5 μs t_{stg}<8 μs				50*			268	ダーリントン T8L20
	〃 1026	〃	〃	〃	100	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	>1500	3	10A	10	−1.5A	t_{on}<2 μs, t_f<3 μs t_{stg}<5 μs				50*			119	ダーリントン T15L10
	〃 1027	〃	〃	〃	200	200	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	200	3000	3	10A	10	−1.5A	t_{on}<2 μs, t_f<5 μs t_{stg}<8 μs				50*			119	ダーリントン T15L20
★	〃 1028	三洋																							
★	〃 1029	〃	PA	Si. TP	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	120	2	1 A										268	
	〃 1030	松下	AF	Si. EP	50	40	50	200	125	0.1	20	400~2000	10	2							120*	2.6		176	
★	〃 1031	サンケン	PA	Si. TMe	120	120	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	120	4000	2.2	4 A										298	ダーリントン
★	〃 1032	松下	〃	Si. TP	60	60	4 A	60W (Tc=25°C)	150	400	60	40~250	4	3 A			t_{on}=0.2μs, t_{off}=1.4μs							365	2SB812 とコンプリ ○
	〃 1033	日電	〃	Si. T	200	150	2 A	20W (Tc=25°C)	150	50	150	40~200	10	400	10	−400					10*			185	2SB768 とコンプリ
★	〃 1034	東芝	SW	Si. TMe	600	450	300A	1250W (Tc=25°C)	125	2 mA	600	300	5	300A			t_{on}<5 μs, t_f<20μs t_{stg}<15μs							356	
	〃 1035	富士通	〃	Si. P	150	120	3 A	40W (Tc=25°C)	150	1	80	50	4	1 A			t_r=1.1μs, t_f=1.5μs t_{stg}=3.5μs							268	ダーリントン
	〃 1036	〃	〃	〃	150	120	15A	150W (Tc=25°C)	150	1	80	35	4	5 A			t_r=1.2μs, t_f=1.8μs t_{stg}=3.2μs							163	
	〃 1037	〃	〃	〃	150	120	30A	180W (Tc=25°C)	150	5	80	35	4	10A			t_r=1.2μs, t_f=1.6μs t_{stg}=2.9μs							163	
	〃 1038	〃	〃	〃	150	120	40A	180W (Tc=25°C)	150	5	80	40	4	15A			t_r=1.3μs, t_f=2 μs t_{stg}=3 μs							163	
	〃 1039	〃	〃	〃	150	120	3 A	40W (Tc=25°C)	150	1	80	50	4	1 A			t_r=1.1μs, t_f=1.5μs t_{stg}=3.5μs							99	
	〃 1040	〃	〃	〃	150	120	15A	120W (Tc=25°C)	150	1	80	35	4	5 A			t_r=1.2μs, t_f=1.8μs t_{stg}=3.2μs							102	○
	〃 1041	〃	〃	〃	150	120	30A	200W (Tc=25°C)	150	5	80	35	4	10A			t_r=1.2μs, t_f=1.6μs t_{stg}=2.9μs							102	
	〃 1042	〃	〃	〃	150	120	40A	200W (Tc=25°C)	150	5	80	40	4	15A			t_r=1.3μs, t_f=2 μs t_{stg}=3 μs							103	
★	〃 1043	松下	PA	Si. TP	400	400R	5 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	1000	5	5 A										102	ダーリントン ダンパ内蔵
★	〃 1044	〃	〃	Si. DJ	100	80	6 A	60W (Tc=25°C)	150	10	100	700~10000	4	1 A										365	ダーリントン ダンパ内蔵 ○
★	〃 1045	日立	AF. SW	Si. E	30	10	3 A	900	150	1	10	160~800	2	100	2	−100					200*	30		251	
	〃 1046	三洋	PA. SW	Si. P	150	120	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	80	60~200	5	1 A	5	−1A					15*	160		346	2SB816 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1047	三洋	PA. SW	Si. P	160	140	12A	100W (Tc=25°C)	150	100	80	60~200	5	1 A	5	−1A					15 *	210		346	2SB817 とコンプリ
〃 1048	〃	AF	Si. EP	20	15	700	200	125	0.1	15	160~960	2	50	10	−50					250 *	8		176	2SB815 とコンプリ
〃 1049	富士電機	SW	Si. TP	120	80	25A	80W (Tc=25°C)	150	100	120	>20	5	25A			t_{on}<1 μs, t_f<0.4μs t_{stg}<2.5μs							211	
〃 1050	日立	〃	Si. E	100	100	10A	80W (Tc=25°C)	150	100	100	2000	3	5 A										332	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1051	松下	〃	Si. EP	50	40	1.5A	1 W	150	1	20	30~220	5	1 A	5	−500					150 *	45		151	2SB819 とコンプリ
〃 1052	東芝	〃	Si. T	50	50	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	50	400	5	500										268	○
〃 1053	日電	〃	〃	400	350	1 A	15W (Tc=25°C)	150	10	350	50	5	100										185	
★ 〃 1054	日立	〃	〃	300	250	3 A	80W (Tc=25°C)	150	100	300	20	5	1 A										102	
〃 1055	ローム	AF	Si. EP	40	32	2 A	750	135	1	20	180	3	500	5	−500					100 *	50		235	2SB822 とコンプリ
〃 1056	富士電機	SW. PA	Si. TP	600	600	50A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	>100	5	50A			t_{on}<3 μs, t_f<4 μs t_{stg}<12μs							254	ダーリントン
★ 〃 1057																								
★ 〃 1058																								
★ 〃 1059	三洋	PA	Si. TP	100	85	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	110	5	1 A										268	
〃 1060	〃	〃	Si. EP	60	50	5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	120	2	1 A										268	
〃 1061	〃	PA. SW	〃	60	50	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	110	2	1 A			t_{on}<0.2μs, t_f<0.3μs t_{stg}<0.9μs							268	
〃 1062	〃	〃	〃	60	50	12A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	110	2	1 A			t_{on}<0.1μs, t_f<0.05μs t_{stg}<1.2μs							268	
〃 1063	〃	〃	〃	60	50	7 A	60W (Tc=25°C)	150	100	40	110	2	1 A			t_{on}<0.2μs, t_f<0.3μs t_{stg}<0.9μs							346	
〃 1064	〃	〃	〃	60	50	12A	80W (Tc=25°C)	150	100	40	110	2	1 A			t_{on}<0.1μs, t_f<0.05μs t_{stg}<1.2μs							346	
★ 〃 1065	〃	〃	〃	60	50	15A	90W (Tc=25°C)	150	100	40	110	2	1 A										346	
〃 1066	富士電機	SW	Si. TP	600	600	100A	770W (Tc=25°C)	125	1 mA	600	>100	5	100A			t_{on}<4 μs, t_f<4 μs t_{stg}<12μs							221	ダーリントン
〃 1067	〃	〃	〃	600	600	30A	200W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	200	5	30A			t_{on}<3 μs, t_f<4 μs t_{stg}<12μs							254	ダーリントン
★ 〃 1068	ソニー	SW	Si. Pa	1000	900	10	25W (Tc=25°C)	120	I_{CES} 10	1000	>50	5	1	10	−1					8.5 *	4.5		268	2SB832 とコンプリ
〃 1069	東芝	〃	Si. T	300	150	7 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	20	1.5	5 A			t_f<1 μs							268	水平偏向用
〃 1070	日電	PA. SW	Si. E	100	60	10A	60W (Tc=25°C)	150	10	60	40~200	1	3 A										162	
〃 1071	富士電機	PA	Si. TP	300	300	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	300	1500	2	4 A										268	ダーリントン
〃 1072	〃	SW	〃	500	500	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	450	2500	3	3 A										268	ダーリントン
〃 1073	〃	PA	〃	300		4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	300	3000	2	2 A										268	ダーリントン
★ 〃 1074	日立	〃	Si. E	120	80	1 A	10W (Tc=25°C)	150	10	100	160	5	150										245	
★ 〃 1075	〃	〃	〃	120	100	1 A	10W (Tc=25°C)	150	10	100	100	5	150										245	
〃 1076	〃	〃	〃	25	25	2.5A	20W (Tc=25°C)	150	20	25	160	2	500										245	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SD1077	日立	PA	Si. E	35	35	2.5A	20W (Tc=25°C)	150	20	35	160	2	500										245	2SB837 とコンプリ
	〃 1078	〃	〃	〃	50	50	2 A	20W (Tc=25°C)	150	5	50	100	4	50	4	−50					130 *			245	
	〃 1079	〃	〃	〃	80	80	2 A	20W (Tc=25°C)	150	5	50	100	4	50	4	−50					130 *			245	
	〃 1080	〃	〃	〃	180	120	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	10	160	100	5	150	5	−500					140 *	14		245	2SB840 とコンプリ
	〃 1081	〃	〃	〃	180	160	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	10	160	100	5	150	5	−500					140 *	14		245	2SB841 とコンプリ
	〃 1082	〃	〃	〃	200	160	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	10	160	100	5	150										245	
	〃 1083	〃	PA. SW	Si. EP	150	60	2 A	10W (Tc=25°C)	150	1	100	200	5	1.5A			t_f<0.6μs							245	水平偏向用
★	〃 1084	〃	PA	Si. T	500	400	50A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	500	300	5	50A										351	ダーリントン
	〃 1085	〃	〃	Si. E	300	300	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	300	3000	2	2 A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
★	〃 1086	東芝																							
	〃 1087	〃	AF.PA.SW	Si. T	100	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	3000	3	15A			t_{on}< 2 μs, t_f< 5 μs t_{stg}<20μs							125	ダーリントン
	〃 1088	〃	〃	〃	300	250	6 A	30W (Tc=25°C)	150	500	300	5000	2	2 A			t_{on}< 2 μs, t_f<10μs t_{stg}<20μs							268	ダーリントン
★	〃 1089	〃	〃	〃	350	350	6 A	30W (Tc=25°C)	150	500	300	1000	2	2 A			t_{on}<20μs, t_f<10μs t_{stg}<20μs							268	ダーリントン
	〃 1090	〃	PA	〃	200	180	5 A	80W (Tc=25°C)	150	100	200	1000	5	1 A										203	
	〃 1091	松下	〃	Si. TP	170	170R	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	170	5000	4	1 A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
	〃 1092	東芝	〃	Si. T	45	45	4 A	80W (Tc=25°C)	150	100	40	1000	5	500										203	
	〃 1093	日立	PA. SW	〃	1000	400	7 A	50W (Tc=25°C)	150	100	100	20	5	2.5A			t_{on}< 5 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<10μs							102	
	〃 1094	〃	SW	〃	1000	400	10A	50W (Tc=25°C)	150	100	1000	30	5	2.5A			t_{on}< 5 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							102	
★	〃 1095	〃	〃	〃	1200	1200S	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	500	600	8	5	300			t_f< 1 μs							102	水平偏向用
★	〃 1096	〃	PA	Si. E	25	20	1 A	10W (Tc=25°C)	150	1	20	140	2	500										245	
★	〃 1097	〃	SW	Si. T	1200	1200S	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	500	600	8	5	300			t_f< 1 μs							102	水平偏向用
★	〃 1098	〃	〃	〃	1200	1200S	3 A	50W (Tc=25°C)	150	500	600	8	5	300			t_f<0.8μs							102	水平偏向用
★	〃 1099	〃	〃	〃	1200	1200S	5 A	50W (Tc=25°C)	150	500	600	12	5	1 A			t_f<1.2μs							102	水平偏向用
★	〃 1100	〃	AF	Si. E	20	16	2 A	900	150	2	16	400	2	100										251	
	〃 1101	〃	〃	〃	25	20	700	150	150	1	20	140	1	150										176	2SB831 とコンプリ
★	〃 1102	〃	SW	Si. T	1200	1200S	4 A	50W (Tc=25°C)	150	500	600	10	5	1 A			t_f< 1 μs							102	水平偏向用
★	〃 1103	〃	〃	〃	1200	1200S	5 A	50W (Tc=25°C)	150	500	600	12	5	1 A			t_f< 1 μs							102	水平偏向用
★	〃 1104	〃	〃	〃	1200	1200S	6 A	50W (Tc=25°C)	150	500	600	12	5	1 A			t_f<1.2μs							102	水平偏向用
★	〃 1105	松下	PA	Si. DJ	120	80	15A	200W (Tc=25°C)	150	30	40	80	4	5 A	10	−500					1 *			102	
★	〃 1106	日電	〃	Si. T	450	450	50A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	300	5	50A										359	ダーリントン

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
★	2SD1107	日電	PA	Si. T	500	500	50A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	500	300	5	50A										359	ダーリントン	
★	〃 1108	〃						10W (Tc=25°C)																		
★	〃 1109	〃	PA	Si. T	100	100	6 A	70W (Tc=25°C)	150	50	100	80	5	1 A										162		○
	〃 1110	〃	〃	〃	120	120	7 A	80W (Tc=25°C)	150	50	120	80	5	1 A	5	−200					15 *	190		162	2SB849 とコンプリ	○
	〃 1111	三洋	AF	Si. EP	80	50	700	600	150	0.1	40	25000	2	50										138	ダーリントン	
	〃 1112	松下	〃	Si. TP	300	300	200	10W (Tc=25°C)	150	10	300	120	10	10	30	−10					70 *	3.5		361		
	〃 1113	日立	PA	Si. T	300	300	6 A	40W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} 100	300	3000	2	4 A										268	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 1114	〃	〃	〃	400	300	6 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} 100	300	>500	2	4 A			t_{on} = 2 μs, t_{off} = 23μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 1115	〃	〃	〃	400	300	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	300	3000	2	2 A										268	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 1116	〃	〃	〃	400	300	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	300	3000	2	2 A										268	ダーリントン	
	〃 1117	富士電機	〃	Si. TP	40	40	10A	50W (Tc=25°C)	150	10	40	120	5	2 A										268		○
	〃 1118	〃	SW	〃	80	50	10A	50W (Tc=25°C)	150	10	80	400	5	1 A			t_{on}<0.3μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs							268		
	〃 1119	松下	AF	Si. EP	40	25	3 A	500	150	0.1	10	260	2	500	6	−50					150 *	<50		336		
	〃 1120	〃	PA	Si. TP	200	150	2 A	40W (Tc=25°C)	150	100	200	1000	4	200										268		
	〃 1121	〃	〃	〃	200	150	3 A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	1000	4	1 A										268		
	〃 1122	〃	〃	〃	200	150	5 A	80W (Tc=25°C)	150	100	200	1000	4	1 A										365		
	〃 1123	〃	〃	〃	200	150	8 A	100W (Tc=25°C)	150	100	200	1000	4	1 A										365		
	〃 1124	〃	〃	〃	80	60	8 A	80W (Tc=25°C)	150	100	80	1000	4	1 A										365		
	〃 1125	〃	〃	〃	80	60	12A	100W (Tc=25°C)	150	100	80	1000	4	1 A										365		
	〃 1126	日立	PA. SW	Si. T	120	120	10A	50W (Tc=25°C)	150	100	120	3000	3	5 A			t_{on}< 2 μs, t_{off}<16μs t_{stg}<12μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 1127	〃	〃	〃	120	120	10A	50W (Tc=25°C)	150	100	120	3000	2	10A			t_{on}< 2 μs, t_{off}<16μs t_{stg}<12μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵	
	〃 1128	富士電機	PA	Si. TP	150	100	5 A	30W (Tc=25°C)	150	1 mA	150	5000	4	1 A	5	−500					22 *	54		268	ダーリントン	
	〃 1129	日立	PA. SW	Si. E	100	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	3000	3	8 A			t_{on}<2.5μs, t_{off}<10μs t_{stg}< 4 μs							332	ダーリントン	
	〃 1130	〃	〃	〃	100	100	20A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	3000	3	10A			t_{on}<2.5μs, t_{off}<10μs t_{stg}< 4 μs							332	ダーリントン	
★	〃 1131	〃	PA	Si. T	50	50	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	20	100	4	1 A	4	−500					8 *			268		
★	〃 1132	〃	〃	〃	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	20	100	4	1 A	4	−500					8 *			268		
	〃 1133	〃	〃	〃	70	50	4 A	40W (Tc=25°C)	150	1	50	100	4	1 A	4	−500					7 *			268	2SB857 とコンプリ	
	〃 1134	〃	〃	〃	70	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	1	50	100	4	1 A	4	−500					7 *			268	2SB858 とコンプリ	
	〃 1135	〃	〃	〃	100	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	100	5	1 A	5	−500					10 *	40		268	2SB859 とコンプリ	
	〃 1136	〃	〃	〃	200	80	4 A	30W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	45	5	4 A										268	水平偏向用	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1137	日立	PA	Si. T	100	100	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	120	4	500										268	2SB860 とコンプリ
〃 1138	〃	〃	〃	200	150	2 A	30W (Tc=25°C)	150	1	120	140	4	50								20		268	2SB861 とコンプリ
★ 〃 1139	〃	〃	〃	200	150	2 A	30W (Tc=25°C)	150	100	120	120	4	50										268	
〃 1140	東芝	SW	Si. E	30	30	1.5A	900	150	10	30	7000	2	150			t_{on}<0.4μs, t_f<0.6μs t_{stg}<1.2μs							241	ダーリントン
〃 1141	日立	PA	Si. T	400	300	6 A	40W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} 100	300	3000	2	4 A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
★ 〃 1142	日電	SW	Si. TMe	1500	1500S	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	20	1000	12	10	500			t_{stg}<12μs, t_f<1 μs							102	水平偏向用
〃 1143	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	50W (Tc=25°C)	150	20	1000	12	10	1 A			t_{stg}<15μs, t_f<1 μs							102	水平偏向用
★ 〃 1144	〃																							
〃 1145	三洋	AF. SW	Si. EP	60	20	5 A	900	150	1	50	100~560	2	500	10	−50					120*	45		294	
★ 〃 1146	ソニー	AF	Si. E	50	50	2 A	900	150	1	40	300	2	10										294	
〃 1147	富士電機	PA	Si. TP	120	80	5 A	30W (Tc=25°C)	150	1 mA	120	5000	5	1 A	5	−500					22*	54		268	ダーリントン
〃 1148	東芝	〃	Si. T	140	140	10A	100W (Tc=25°C)	150	5	140	100	5	1 A										203	2SB863 とコンプリ
★ 〃 1149	松下	AF	Si. EP	100	100	20	200	125	1	60	1000	10	2										176	
★ 〃 1150	三洋	SW	〃	350	90	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	60	5	3 A				t_f<1 μs						268	水平偏向用
★ 〃 1151	松下	〃	Si.TMe	1500	1500S	5 A	95W (Tc=25°C)	130	100	750	40~150	10	3.5A				t_{stg}=7 μs, t_f<1 μs						102	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1152	日立	AF	Si. E	55	50	100	200	125	0.5	18	500	12	2										138	
〃 1153	三洋	AF. SW	Si. EP	80	50	1.5A	900	150	0.1	40	>4000	2	500	10	−50					120*			294	2SB865 とコンプリ ダーリントン
★ 〃 1154	松下	SW	Si. E	350	200	7 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	30	4	5 A			t_{stg}<2 μs, t_f<0.75μs							102	水平偏向用
〃 1155	富士電機	〃	Si. TP	400	400	50A	300W (Tc=25°C)	150	1 mA	400	400	5	50A			t_{on}<2 μs, t_f<2.5μs t_{stg}<10μs							254	ダーリントン
〃 1156	三菱	PA	Si. EP	100	80	5 A	58W (Tc=25°C)	150	2.5	50	110	5	2.5A										358	
〃 1157	富士電機	AF. PA	Si. TP	80	50	4 A	25W (Tc=25°C)	150	100	80	400	5	500										268	
〃 1158	〃	AF. PA. SW	〃	80	50	8 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	400	5	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.8μs t_{stg}<3 μs							268	
〃 1159	三洋	SW	Si. T	200	60	4.5A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	80	5	1 A			t_f<1 μs							268	水平偏向用
〃 1160	東芝	PA, SW	Si. E	50	50S	2 A	1 W	150	1	30	200	2	1 A			t_r<0.25μs, t_f<0.25μs t_{stg}<1 μs							344	ダンパ内蔵
★ 〃 1161	三洋	AF	Si. EP	30	15	30	150	150	0.1	15	180	6	1										176	
〃 1162	日電	SW	Si. T	500	+300 −10	10A	40W (Tc=25°C)	150	10	400	400~3000	2	2 A			t_{on}=1 μs, t_f=6 μs t_{stg}=12μs							268	ダーリントン
〃 1163	日立	〃	〃	300	120	7 A	40W (Tc=25°C)	150	5 mA	300	40	5	5 A			t_f<0.5μs							268	水平偏向用 ○
〃 1164	日電	PA	Si. E	150	60	±1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	60	2000~30000	2	1 A										186	ダンパ内蔵 ダーリントン
★ 〃 1165	東芝	SW	Si. TMe	1000	900	100A	1250W (Tc=25°C)	125	2 mA	1000	150	5	100A			t_{on}<3 μs, t_f<8 μs t_{stg}<30μs							356	ダーリントン
〃 1166	〃	〃	〃	1000	900	200A	2500W (Tc=25°C)	125	3 mA	1000	200	5	200A			t_{on}<3 μs, t_f<8 μs t_{stg}<30μs							357	ダーリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★ 2SD1167																								
★ 〃 1168	松下	SW	Si.TMe	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	130	100	750	15	4	1 A			t_{on}<1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}=2 μs							102	
〃 1169	〃	PA	Si.TP	150	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	150	10000	4	1 A										268	ダーリントン
〃 1170	サンケン	〃	Si.TMe	120	120	6 A	70W (Tc=25°C)	150	100	120	4000	4	3 A										324	ダーリントン
★ 〃 1171	松下	SW	〃	1500	1500S	5 A	50W (Tc=25°C)	130	1 mA	1500	15	10	2 A			t_{stg}<10μs, t_f<0.8μs							102	水平偏向用ダンパ内蔵
★ 〃 1172	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	65W (Tc=25°C)	130	1 mA	1500	15	10	2.5A			t_{stg}<10μs, t_f<0.8μs							102	水平偏向用ダンパ内蔵
★ 〃 1173	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	70W (Tc=25°C)	130	1 mA	1500	15	10	3 A			t_{stg}<10μs, t_f<0.8μs							102	水平偏向用ダンパ内蔵
★ 〃 1174	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	95W (Tc=25°C)	130	1 mA	1500	15	10	4 A			t_{stg}<10μs, t_f<0.8μs							102	水平偏向用ダンパ内蔵
★ 〃 1175	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	100W (Tc=25°C)	130	1 mA	1500	15	10	5 A			t_{stg}<12μs, t_f<0.7μs							102	水平偏向用ダンパ内蔵
〃 1176	〃	PA.SW	Si.P	60	60	8 A	45W (Tc=25°C)	150	100	60	4000	3	4 A			t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<6 μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵 ○
〃 1177	日立	AF.PA	Si.E	100	60	2 A	20W (Tc=25°C)	150	10	80	100	5	500	5	−500					230*	50		160	2SB874 とコンプリ
〃 1178	〃	〃	〃	100	80	2 A	20W (Tc=25°C)	150	10	80	100	5	500										160	
〃 1179	〃	〃	Si.T	120	100	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	10	100	100	5	150										160	
〃 1180	〃	〃	Si.E	120	110	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	100	100	5	150										160	
〃 1181	〃	〃	〃	180	120	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	160	140	5	150										234D	
〃 1182	〃	〃	〃	180	160	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	160	140	5	150										234D	
〃 1183	〃	SW	Si.T	1200	800	3 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1200	14	5	300			t_{on}<2 μs, t_f<1 μs t_{stg}<10μs							102	
〃 1184	〃	〃	〃	1500	800	3 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1500	14	5	300			t_{on}<2 μs, t_f<1 μs t_{stg}<10μs							102	
〃 1185	〃	〃	〃	1200	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1200	15	5	300			t_{on}<2 μs, t_f<1 μs t_{stg}<10μs							102	
〃 1186	〃	〃	〃	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1500	15	5	300			t_{on}<2 μs, t_f<1 μs t_{stg}<10μs							102	
〃 1187	東芝	AF.PA.SW	〃	100	80	10A	80W (Tc=25°C)	150	10	100	110	1	1 A			t_{on}<1.8μs, t_f<2.4μs t_{stg}<9 μs							203	
★ 〃 1188																								
〃 1189	ローム	AF.PA	Si.EP	40	32	2 A	5 W (Tc=25°C)	150	1	20	180	3	500	5	−500					100*	30		232	2SB891 とコンプリ
〃 1190	三洋	PA	〃	70	60	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	2 A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1191	〃	〃	〃	70	60	7 A	35W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	3.5A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1192	〃	〃	〃	70	60	10A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	5 A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1193	〃	〃	〃	70	60	15A	70W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	7 A										346	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1194	〃	〃	Si.TP	110	100	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	1.5A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1195	〃	〃	〃	110	100	5 A	35W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	2.5A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1196	〃	〃	〃	110	100	8 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	4 A										268	ダーリントン ダンパ内蔵

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1197	三洋	PA	Si.TP	110	100	10A	70W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	5A	5	−5A					20 *			346	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1198	松下	AF	Si.EP	30	25	1A	750	150	0.1	25	7000	10	1A										151	ダーリントン ○
〃 1199	〃	〃	〃	40	40	50	400	150	0.1	10	300	2	500										151	
〃 1200	ローム	AF.PA	〃	80	80	700	5W (Tc=25°C)	150	0.5	50	180	3	100	10	−50					120 *	10		232	2SB889 とコンプリ
〃 1201	日立	SW	Si.T	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	100	3	10A			t_{on}<8μs, t_f<12μs t_{stg}<8μs							102	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1202	〃	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	5	500	100	3	10A			t_{on}<5μs, t_f<6μs t_{stg}<4μs							102	ダーリントン
〃 1203	〃	〃	〃	500	400	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	100	3	15A			t_{on}<8μs, t_f<12μs t_{stg}<8μs							102	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1204	〃	〃	〃	500	400	15A	100W (Tc=25°C)	150	5	500	100	3	15A			t_{on}<5μs, t_f<6μs t_{stg}<4μs							102	ダーリントン
〃 1205	松下	AF	Si.EP	30	25	500	400	150	0.1	25	8000	10	500										151	ダーリントン ○
〃 1206	〃	〃	〃	30	25	100	400	150	1	10	300	10	2										151	2SB894 とコンプリ
〃 1207	三洋	PA	〃	60	50	2A	1W	150	0.1	50	200	2	500										294	
〃 1208	東芝	〃	Si.T	45	45	5A	100W (Tc=25°C)	150	1	45	5000	5	500										102	ダーリントン
〃 1209	日立	AF	Si.E	60	60	1A	900	150	100	60	60000	3	500										251	ダーリントン
〃 1210	日電	PA	〃	150	100	±10A	80W (Tc=25°C)	150	10	100	9000	2	10A			t_{on}=1μs, t_f=2μs t_{stg}=5μs							162	ダンパ内蔵 ダーリントン
★ 〃 1211	松下	AF	Si.EP	120	120	500	1W	150			90~330	10	150	10	−50					200 *	<20		294	2SB987 とコンプリ
〃 1212	三洋	PA	〃	60	30	12A	35W (Tc=25°C)	150	100	40	150	2	1A										268	
〃 1213	〃	〃	〃	60	30	20A	60W (Tc=25°C)	150	100	40	150	2	1A										346	
〃 1214	松下	PA.SW	Si.TP	30±5	30±5	2A	35W (Tc=25°C)	150	100	25	5000	4	2A			t_{on}<1μs, t_f<2μs t_{stg}<5μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1215	〃	〃	〃	30±5	30±5	4A	40W (Tc=25°C)	150	100	25	5000	3	3A			t_{on}<1μs, t_f<2μs t_{stg}<6μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1216	〃	〃	〃	30±5	30±5	8A	45W (Tc=25°C)	150	100	25	5000	3	4A			t_{on}<1μs, t_f<2μs t_{stg}<7μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1217	〃	〃	〃	60±10	60±10	2A	35W (Tc=25°C)	150	100	50	5000	4	2A			t_{on}<1μs, t_f<2μs t_{stg}<5μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1218	〃	〃	〃	60±10	60±10	4A	40W (Tc=25°C)	150	100	50	5000	3	3A			t_{on}<1μs, t_f<2μs t_{stg}<6μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1219	〃	〃	〃	60±10	60±10	8A	45W (Tc=25°C)	150	100	50	5000	3	4A			t_{on}<1μs, t_f<2μs t_{stg}<7μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1220	東芝	PA	Si.E	150	150	1.5A	1W	150	1	150	120	5	200	5	−200					100 *	13		344	2SB905 とコンプリ
〃 1221	〃	AF.PA	Si.T	60	60	3A	20W (Tc=25°C)	150	100	60	150	5	500	5	−500					3 *	70		344	2SB906 とコンプリ
〃 1222	〃	PA	Si.E	60	40	3A	1W	150	1	60	5000	2	1A										344	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1223	〃	〃	〃	100	80	4A	1W	150	1	100	5000	2	1A										344	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1224	〃	〃	〃	30	30	1.5A	1W	150	10	30	10000	2	150										344	ダーリントン
〃 1225	ローム	AF	Si.EP	40	32	1A	1W	135	0.5	20	180	3	100										360	
〃 1226	〃	〃	〃	80	80	700	1W	135	0.5	50	180	3	100										360	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
2SD1227	ローム	AF	Si.EP	40	32	2 A	1 W	135	1	20	180	3	500										360		
〃 1228	〃	〃	〃	50	50	500	1 W	125	0.5	30	180	3	100										360		
〃 1229	三洋	PA	〃	70	60	10A	60W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	5 A										346	ダーリントンダンパ内蔵	
〃 1230	〃	〃	Si.TP	110	100	8 A	60W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	4 A										346	ダーリントンダンパ内蔵	
〃 1231	〃	〃	Si.EP	70	60	10A	70W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	5 A	5	−5A	t_{on}=0.6μs, t_f=1.8μs t_{stg}=3 μs				20 *			102	ダーリントンダンパ内蔵	
〃 1232	〃	〃	〃	70	60	15A	80W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	7 A	5	−7A					20 *			102	ダーリントンダンパ内蔵	
〃 1233	〃	〃	Si.TP	110	100	8 A	70W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	4 A										102	ダーリントンダンパ内蔵	
〃 1234	〃	〃	Si.EP	110	100	10A	80W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	5 A	5	−5A					20 *			102	ダーリントンダンパ内蔵	
〃 1235	〃	〃	〃	60	30	8 A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	150	2	1 A	5	−1A	t_{on}=0.1μs, t_f=0.03μs t_{stg}=0.5μs				120 *			268		
〃 1236	〃	〃	〃	120	80	5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	150	2	1 A										268		
〃 1237	〃	〃	〃	120	80	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	150	2	1 A										268		
〃 1238	〃	〃	〃	120	80	12A	80W (Tc=25°C)	150	100	80	150	2	1 A	5	−1A					20 *			346	2SB922とコンプリ	
〃 1239	〃	〃	〃	120	80	20A	100W (Tc=25°C)	150	100	80	150	2	1 A										102		
〃 1240	〃	〃	〃	120	80	25A	120W (Tc=25°C)	150	100	80	150	2	1 A										102		
〃 1241	松下	AF.PA	Si.DJ	60	60	5 A	60W (Tc=25°C)	150	30	20	80	3	1 A										365		○
〃 1242	〃	〃	〃	60	60	6 A	70W (Tc=25°C)	150	30	20	80	3	2 A										365		○
〃 1243	〃	〃	〃	60	60	10A	100W (Tc=25°C)	150	30	20	80	3	3 A										365		○
〃 1244	〃	〃	Si.EP	40	20	5 A	1 W	150	0.1	10	280	2	500	6	−50					150 *	<50		151	2SB1050とコンプリ	
〃 1245	〃	PA	Si.T	500	400	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	350	500~5000	2	2 A										268	ダーリントンダンパ内蔵	
〃 1246	三洋	AF.PA	Si.EP	30	25	2 A	750	150	0.1	20	300	2	100										138	2SB926とコンプリ	
〃 1247	〃	PA	〃	30	25	2.5A	1 W	150	0.1	20	300	2	100										294		
〃 1248	日立	〃	Si.T	120	120	8 A	40W (Tc=25°C)	150	100	120	7000	3	4 A										268	ダーリントンダンパ内蔵	
〃 1249	松下	PA	Si.TP	350	250	750	35W (Tc=25°C)	150	1 mA	350	40~250	10	300										363		○
〃 1250	〃	〃	〃	200	150	2 A	30W (Tc=25°C)	150	50	200	64~240	10	150										363	2SB928とコンプリ	○
〃 1251	〃	〃	〃	60	60	3 A	30W (Tc=25°C)	150	30	20	30~160	3	1 A							$f_{\alpha e}$ 25kHz			363		○
〃 1252	〃	〃	〃	60	60	3 A	35W (Tc=25°C)	150			40~250	4	1 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.4μs t_s=2.5μs							363	2SB929とコンプリ	○
〃 1253	〃	〃	〃	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150			40~250	4	1 A			t_{on}=0.4μs, t_f=0.5μs t_s=1.2μs							363	2SB930とコンプリ	○
〃 1254	〃	SW	Si.EP	130	80	3 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	60~260	2	500			t_{on}=0.5μs, t_f=0.15μs t_s=2.5μs				30 *			363	2SB931とコンプリ	
〃 1255	〃	〃	〃	130	80	4 A	35W (Tc=25°C)	150	10	100	60~260	2	1 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.15μs t_s=2.5μs				30 *			363	2SB932とコンプリ	
〃 1256	〃	〃	〃	130	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	60~260	2	2 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.15μs t_s=1.5μs				30 *			363	2SB933とコンプリ	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
2SD1257	松下	SW	Si.EP	130	80	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	60~260	2	3 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.1μs t_s=1.5μs				30 *			363	2SB934 とコンプリ	○
〃 1258	〃	PA	Si.TP	200	150	1 A	40W (Tc=25°C)	150	100	200	500~2000	4	200	4	−100					25 *			363		
〃 1259	〃	〃	〃	80	60	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	500~1500	4	500	12	−200					50 *			363		○
〃 1260	〃	〃	〃	60	60	2 A	35W (Tc=25°C)	150	1 mA	60	1000~10000	4	2 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1 μs t_s=4 μs							363	ダーリントン 2SB937 とコンプリ	○
〃 1261	〃	〃	〃	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	200	60	1000~10000	3	3 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1 μs t_s=4 μs							363	ダーリントン 2SB938 とコンプリ	○
〃 1262	〃	SW	〃	60	60	8 A	45W (Tc=25°C)	150	100	60	1000~10000	3	4 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1 μs t_s=4 μs							363	ダーリントン 2SB939 とコンプリ	○
〃 1263	〃	PA	〃	350	250	750	35W (Tc=25°C)	150			40~250	10	300			t_{on}=0.5μs, t_f=0.5μs t_s=2.0μs							364		○
〃 1264	〃	〃	〃	200	180	2 A	30W (Tc=25°C)	150	50	200	60~240	10	150										364	2SB940 とコンプリ	○
〃 1265	〃	〃	〃	60	60	4 A	30W (Tc=25°C)	150	30	20	30~160	3	1 A							$f_{\alpha e}$ 25kHz			364		○
〃 1266	〃	〃	〃	60	60	3 A	35W (Tc=25°C)	150			40~250	4	1 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.4μs t_s=2.5μs							364	2SB941 とコンプリ	○
〃 1267	〃	〃	〃	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150			40~250	4	1 A										364	2SB942 とコンプリ	○
〃 1268	〃	SW	Si.EP	130	80	3 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	60~260	2	500			t_{on}=0.5μs, t_f=0.15μs t_s=2.5μs				30 *			364	2SB943 とコンプリ	
〃 1269	〃	〃	〃	130	80	4 A	35W (Tc=25°C)	150	10	100	60~260	2	1 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.15μs t_s=2.5μs				30 *			364	2SB944 とコンプリ	
〃 1270	〃	〃	〃	130	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	60~600	2	100			t_{on}=0.5μs, t_f=0.15μs t_s=1.5μS				30 *			364	2SB945 とコンプリ	
〃 1271	〃	〃	〃	130	80	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	60~260	2	3 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.1μs t_s=1.5μs				30 *			364	2SB946 とコンプリ	○
〃 1272	〃	PA	Si.TP	200	150	1 A	40W (Tc=25°C)	150	100	200	500~2000	4	200	4	−100					25 *			364		
〃 1273	〃	〃	〃	80	60	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	500~1500	4	500	12	−200					50 *			364		○
〃 1274	〃	PA.SW	〃	150	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	150	14~100	4	5 A			t_{stg}< 6 μs t_f<1.0μs							364		○
〃 1275	〃	PA	〃	60	60	2 A	35W (Tc=25°C)	150	1 mA	60	1000~10000	4	2 A			t_{on}=0.5μs, t_f<1.0μs t_s=4.0μs							364	ダーリントン 2SB949 とコンプリ	○
〃 1276	〃	〃	〃	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	200	60	1000~10000	3	3 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.0μs t_s=4.0μs							364	ダーリントン 2SB950 とコンプリ	○
〃 1277	〃	SW	〃	60	60	8 A	45W (Tc=25°C)	150	100	60	1000~10000	3	4 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.0μs t_s=4.0μs							364	ダーリントン 2SB951 とコンプリ	○
〃 1278	〃	PA.SW	Si.TMe	1200	650	8 A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	1200	8	5	5 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 4 μs							102		
〃 1279	東芝	SW	〃	1400	600	10A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	2 A				t_f< 1 μs						102	水平偏向用	
〃 1280	松下	AF	Si.EP	20	18	1 A	1 W (Tc=25°C)	150	1	10	90~360	2	500	6	−50					150 *	12		336	2SB956 とコンプリ	
〃 1281	日立	PA	Si.E	100	60	2 A	20W (Tc=25°C)	150	0.1	80	100	5	500	5	−1.5A					230 *	50		245	2SB957 とコンプリ	
〃 1282	〃	〃	〃	100	80	2 A	20W (Tc=25°C)	150	0.1	80	100	5	500										245		
〃 1283	〃	〃	〃	120	100	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	0.1	100	120	5	150										245		
〃 1284	〃	〃	〃	120	110	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	0.1	100	100	5	150										245		
★ 〃 1285																									
〃 1286	日電	PA	Si.E	60	60	±1A	8 W (Tc=25°C)	150	10	60	8000	2	500										186	ダーリントン ダンパ内蔵	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1287	日立	PA	Si.T	300	250	30A	150W (Tc=25°C)	150	100	300	300	3	15A										103	ダーリントン
〃 1288	日電	AF.PA	〃	120	120	7 A	70W (Tc=25°C)	150	50	120	140	5	1 A										162	
〃 1289	〃	〃	〃	120	120	8 A	80W (Tc=25°C)	150	50	120	140	5	1 A										162	
〃 1290	松下	SW	Si.TMe	1500	1500S	3 A	50W (Tc=25°C)	130	50	750	3～10	10	2 A			t_{stg}< 7 μs, t_f<1.0μs							365	水平偏向用ダンパ内蔵
〃 1291	〃	〃	〃	1500	1500S	3 A	65W (Tc=25°C)	130	50	750	3～12	10	2.5A			t_{stg}< 8 μs, t_f<1.0μs							365	水平偏向用ダンパ内蔵
〃 1292	ローム	AF	Si.EP	100	80	1 A	900	135	1	80	82～390	3	100	10	−50					100*	20		294	2SB1041とコンプリ
〃 1293	〃	〃	〃	100	80	1 A	1 W	135	1	80	82～390	3	100	10	−50					100*	20		360	
〃 1294	東芝	AF.PA	Si.T	45	45	5 A	80W (Tc=85°C)	150	0.1	45	5000	5	500										203	ダーリントン
〃 1295	松下	PA	Si.EP	50	40	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	20	100	5	1 A										361	
〃 1296	日電	〃	Si.E	150	100	±15A	100W (Tc=25°C)	150	10	100	3500	2	15A			t_{on}= 1 μs, t_f= 2 μs t_{stg}= 5 μs							162	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1297	〃	〃	〃	150	100	25A	100W (Tc=25°C)	150	10	100	10000	2	25A										162	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1298	〃	〃	Si.T	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	600	2	6 A										162	ダーリントンダンパ内蔵
★ 〃 1299	〃	〃	Si.E	150	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	10	100	5000	2	10A										162	ダーリントンダンパ内蔵
★ 〃 1300	日立	〃	Si.T	1500	1500S	3 A	50W (Tc=25°C)	150	50	600	10	5	300										102	
〃 1301	松下	SW	Si.TMe	1500	1500S	2 A	45W (Tc=25°C)	130	50	750	3～12	10	1 A			t_{stg}< 6 μs, t_f<0.8μs							102	水平偏向用ダンパ内蔵
〃 1302	〃	AF	Si.EP	25	20	500	625	150	0.1	25	300	2	500	10	−50					200*	10		138	
〃 1303	〃	PA	〃	20	20	1 A	1 W	150	1	10	200	2	500										294	2SB971とコンプリ
〃 1304	〃	AF	〃	20±3	20±3	100	200	125	0.1	10	300	10	2										176	
〃 1305	〃	〃	〃	185	185	150	200	125	1	100	200	5	10	10	−10					120*	<4.5		176	
〃 1306	日立	〃	Si.E	30	15	700	150	150	1	20	400	1	150	1	−150					250*			176	
〃 1307	松下	PA	Si.T	350	300	6 A	35W (Tc=25°C)	150	100	350	2500	2	2 A										268	ダーリントン
〃 1308	日電	〃	Si.E	150	100	8 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	6000	2	2 A										370	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1309	〃	〃	〃	150	100	8 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	6000	2	3 A										370	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1310	〃	AF.PA	Si.T	60	60	3 A	30W (Tc=25°C)	150	10	60	100	5	500	10	−100					16*	48		370	
〃 1311	〃	〃	〃	100	100	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	100	5	500										370	
〃 1312	〃	PA	Si.E	120	80	1 A	1 W	150	0.1	120	250	1	200										278	
〃 1313	東芝	SW	Si.TMe	800	350	25A	200W (Tc=25°C)	150	1 mA	800	40	5	1 A			t_{on}<2.4μs, t_f<1.5μs t_{stg}< 9 μs							152	
〃 1314	〃	〃	Si.T	600	450	15A	150W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	200	5	15A			t_{on}< 1 μs, t_f< 3 μs t_{stg}<12μs							152	ダーリントン
〃 1315	松下	〃	Si.TP	150	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	150	5000～20000	4	1 A			t_{on}=0.5μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 4 μs							364	ダーリントン
〃 1316	〃	〃	〃	30±5	30±5	2 A	35W (Tc=25°C)	150	100	25	1000～10000	4	2 A			t_{on}=0.4μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 3 μs							363	ダーリントンダンパ内蔵

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1317	松下	SW	Si.TP	30±5	30±5	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	25	1000～10000	3	3 A			t_{on}=0.3μs, t_{stg}=3μs	t_f=1μs						363	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1318	〃	〃	〃	30±5	30±5	8 A	45W (Tc=25°C)	150	100	25	1000～10000	3	4 A			t_{on}=0.5μs, t_{stg}=4μs	t_f=1μs						363	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1319	〃	〃	〃	60±10	60±10	2 A	35W (Tc=25°C)	150	100	50	1000～10000	4	2 A			t_{on}=0.4μs, t_{stg}=3μs	t_f=1μs						363	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1320	〃	〃	〃	60±10	60±10	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	50	1000～10000	3	3 A			t_{on}=0.3μs, t_{stg}=3μs	t_f=1μs						363	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1321	〃	〃	〃	60±10	60±10	8 A	45W (Tc=25°C)	150	100	50	1000～10000	3	4 A			t_{on}=0.5μs, t_{stg}=4μs	t_f=1μs						363	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1322	〃	〃	〃	30±5	30±5	2 A	35W (Tc=25°C)	150	100	25	1000～10000	4	2 A			t_{on}=0.4μs, t_{stg}=3μs	t_f=1μs						364	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1323	〃	〃	〃	30±5	30±5	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	25	1000～10000	3	3 A			t_{on}=0.3μs, t_{stg}=3μs	t_f=1μs						364	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1324	〃	〃	〃	30±5	30±5	8 A	45W (Tc=25°C)	150	100	25	1000～10000	3	4 A			t_{on}=0.4μs, t_{stg}=4μs	t_f=1μs						364	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1325	〃	〃	〃	60±10	60±10	2 A	35W (Tc=25°C)	150	100	50	1000～10000	4	2 A			t_{on}=0.4μs, t_{stg}=3μs	t_f=1μs						364	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1326	〃	〃	〃	60±10	60±10	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	50	1000～10000	3	3 A			t_{on}=0.3μs, t_{stg}=3μs	t_f=1μs						364	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1327	〃	〃	〃	60±10	60±10	8 A	45W (Tc=25°C)	150	100	50	1000～10000	3	4 A										364	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1328	〃	AF	Si.EP	25	20	500	200	125	0.1	25	300	2	500										176	2SB970とコンプリ
〃 1329	日立	PA	Si.T	50	50	6 A	40W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} 100	50	7000	2	3 A										268	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1330	松下	AF	Si.EP	25	20	500	600	150	0.1	25	300	2	500	10	−50					200*	10		151	
★ 〃 1331	日立	〃	Si.E	40	40	1.5A	900	150	1	30	200	2	100										251	
★ 〃 1332	松下	AF.PA	Si.TP	100	100	5 A	60W (Tc=25°C)	150	50	100	100	5	1 A	5	−500					20*	90		365	2SB979とコンプリ
★ 〃 1333	〃	〃	〃	120	120	6 A	70W (Tc=25°C)	150	50	120	100	5	1 A										365	
★ 〃 1334	〃	〃	〃	140	140	7 A	80W (Tc=25°C)	150	50	140	100	5	1 A										365	
★ 〃 1335	〃	〃	〃	150	150	9 A	100W (Tc=25°C)	150	50	150	100	5	1 A										365	
〃 1336	〃	〃	Si.T	200	150	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	200	3000	4	3 A										364	ダーリントンダンパ内蔵 ○
〃 1337	三洋	SW	Si.TMe	1500	600	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1500	15	5	500			t_f<1μs							102	水平偏向用
〃 1338	〃	〃	〃	1500	600	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1500	15	5	500			t_f<1μs							102	水平偏向用ダンパ内蔵
〃 1339	〃	〃	〃	1500	600	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1500	15	5	500			t_f<1μs							102	水平偏向用
〃 1340	〃	〃	〃	1500	600	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1500	15	5	500			t_f<1μs							102	水平偏向用
〃 1341	〃	〃	〃	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1500	15	5	500			t_f<1μs							102	水平偏向用
〃 1342	〃	〃	〃	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1500	15	5	500			t_f<1μs							102	水平偏向用ダンパ内蔵
〃 1343	〃	〃	〃	1500	600	6 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1500	15	5	500			t_f<1μs							102	水平偏向用
〃 1344	〃	〃	〃	1500	600	6 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1500	15	5	500			t_f<1μs							102	水平偏向用ダンパ内蔵
〃 1345	新電元	〃	Si.EP	60	50	7 A	40W (Tc=25°C)	125	100	40	70～200	2	1 A	5	−1A	t_{on}=0.2μs, t_{stg}=0.9μs	t_f=0.3μs			10*			268	2SB983とコンプリ
〃 1346	松下	〃	Si.TMe	1400	1400S	2.5A	40W (Tc=25°C)	150	100	1400	6	10	2 A			t_{stg}<12μs t_f<1μs							268	水平偏向用

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1347	三洋	AF	Si.EP	60	50	3A	1W	150	1	40	250	2	500	10	−50					150*	25		294	2SB985とコンプリ
〃 1348	〃	〃	〃	60	50	4A	10W (Tc=25°C)	150	10	60	250	2	500	10	−50					150*	25		296	2SB986とコンプリ
〃 1349	新電元	SW	Si.T	500	400	7A	50W (Tc=25°C)	150	100	500	>150	2	7A	10	−1A					10*/			268	ダーリントンT7K40
〃 1350	松下	AF.PA	Si.TP	400	400	500	1W	150	0.1	100	100	5	150	30	−20	t_{on}=0.4μs, t_f=0.7μs t_{stg}=3.6μs				55*	<7		151	
〃 1351	韓国電子	〃	Si.T	60	60	3A	30W (Tc=25°C)	150	100	60	145	5	500	5	−500	t_{on}<0.8μs, t_f<0.8μs t_{stg}<1.5μs				3*	70		268	2SB988とコンプリ
〃 1352	〃	〃	〃	80	80	4A	30W (Tc=25°C)	150	30	80	125	5	500	5	−500					8*	90		268	2SB989とコンプリ
★ 〃 1353	東芝	AF	〃	50	50	3A	30W (Tc=25°C)	150	100	50	600	5	500										51	
★ 〃 1354	〃	〃	〃	60	60	3A	30W (Tc=25°C)	150	100	60	150	5	1A										51	2SB994とコンプリ
★ 〃 1355	〃	〃	〃	100	100	5A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	100	5	500										51	2SB995とコンプリ
★ 〃 1356	〃	〃	〃	80	80	4A	30W (Tc=25°C)	150	30	80	100	5	500										51	2SB996とコンプリ
★ 〃 1357	〃	AF.PA.SW	〃	100	100	7A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	6000	3	3A			t_{on}<2.5μs, t_f<5μs t_{stg}<12μs							51	ダーリントンダンパ内蔵
★ 〃 1358	〃	〃	〃	80	80	7A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	6000	3	3A			t_{on}<2.5μs, t_f<5μs t_{stg}<12μs							51	ダーリントンダンパ内蔵
★ 〃 1359	〃	〃	〃	60	60	7A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	6000	3	3A			t_{on}<2.5μs, t_f<5μs t_{stg}<12μs							51	ダーリントンダンパ内蔵
★ 〃 1360	〃	PA.SW	〃	600	400	6A	30W (Tc=25°C)	150	500	600	1000	2	2A			t_{on}<2μs, t_f<10μs t_{stg}<20μs							51	ダーリントン
★ 〃 1361	〃	〃	〃	300	250	6A	20W (Tc=25°C)	150	500	300	5000	2	2A			t_{on}<2μs, t_f<10μs t_{stg}<20μs							51	ダーリントン
★ 〃 1362	〃	〃	〃	100	80	7A	40W (Tc=25°C)	150	5	100	120	1	1A			t_{on}<1.2μs, t_f<1.5μs t_{stg}<7.5μs							51	2SB992とコンプリ
★ 〃 1363	〃	〃	〃	70	50	7A	40W (Tc=25°C)	150	30	70	120	1	1A			t_{on}<0.6μs, t_f<1.5μs t_{stg}<7.5μs							51	2SB993とコンプリ
★ 〃 1364	〃	SW	〃	300	150	7A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	300	20	1.5	5A			t_f<1μs							51	水平偏向用
★ 〃 1365	〃	〃	〃	800	400	3A	40W (Tc=25°C)	150	1mA	800	20	5	500			t_{on}<1μs, t_f<1μs t_{stg}<7μs							51	
〃 1366	日立	AF	Si.E	25	20	1A	1W (プリント基板使用)	150	0.1	20	130	2	500	2	−500					240*	22		336	2SB1000とコンプリ ○
〃 1367	〃	〃	〃	20	16	2A	1W (プリント基板使用)	150	0.1	16	270	2	100	2	−10					100*	20		336	2SB1001とコンプリ
〃 1368	〃	〃	〃	100	50	1A	1W (プリント基板使用)	150	0.1	80	250	2	100	2	−10					100*	20		336	2SB1002とコンプリ
★ 〃 1369	東芝	AF.PA.SW	Si.T	60	40	3A	25W (Tc=25°C)	150	20	60	5000	2	1A			t_{on}<0.2μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs							51	ダーリントンダンパ内蔵
★ 〃 1370	〃	〃	〃	100	80	4A	30W (Tc=25°C)	150	20	100	4000	2	1A			t_{on}<0.2μs, t_f<1.5μs t_{stg}<4μs							51	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1371	三洋	AF.PA	Si.TP	300	300	2A	40W (Tc=25°C)	150	100	200	100	5	300	10	−300	t_f=0.5μs				5*			268	
〃 1372	〃	〃	〃	300	300	4A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	70	5	1A	10	−1A	〃				5*			268	
〃 1373	〃	〃	〃	300	300	3A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	100	5	300	10	−300	〃				5*			346	
〃 1374	〃	〃	〃	300	300	3A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	100	5	300										102	
〃 1375	〃	〃	〃	300	300	4A	90W (Tc=25°C)	150	100	200	70	5	1A										102	
〃 1376	日立	PA	Si.E	120	120	1.5A	8W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	5	1A										160	ダーリントンダンパ内蔵

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	r_{bb} h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1377	日立	PA	Si. E	120	120	8 A	40W (Tc=25°C)	150	100	120	4000	3	4 A										268	ダーリントン
〃 1378	ローム	AF. PA	Si. EP	80	80	700	10W (Tc=25°C)	150	0.5	50	180	3	100	10	−50					120 *	10		74	2SB1007 とコンプリ
〃 1379	〃	〃	〃	40	40	2 A	10W (Tc=25°C)	150	1	24	20000	3	500	6	−100					150 *	11		74	ダーリントン
〃 1380	〃	〃	〃	40	32	2 A	10W (Tc=25°C)	150	1	20	180	3	500	5	−500					100 *	30		74	2SB1009 とコンプリ
〃 1381	〃	〃	〃	120	80	1 A	5 W (Tc=25°C)	150	1	100	180	3	500	10	−50					100 *	20		232	
〃 1382	〃	〃	〃	120	80	1 A	10W (Tc=25°C)	150	1	100	180	3	500	10	−50					100 *	20		74	
〃 1383	〃	AF	〃	40	32	300	200	125	1	24	20000	5	100	5	−10					250 *	3		335	ダーリントン
〃 1384	〃	〃	〃	40	32	2 A	750	125	1	20	180	3	500	5	−500					100 *	50		294	2SB1010 とコンプリ
〃 1385	松下	〃	Si. TP	400	400	100	1.2W	150	10	100	150	50	5	30	−20					40 *	< 7		151	
★ 〃 1386	日立	PA	Si. E	140	140	8 A	50W (Tc=25°C)	150	100	140	4000	3	4 A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1387	三洋	AF. PA	Si. EP	20	16	2 A	700	150	0.1	20	250	2	100										138	2SB1013 とコンプリ
〃 1388	〃	〃	〃	60	50	1 A	700	150	0.1	20	250	2	100										138	2SB1014 とコンプリ
〃 1389	サンケン	PA	Si. TMe	1200	650	6 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	1200	15	4	1 A										102	
〃 1390	松下	SW	〃	1500	1500S	1 A	40W (Tc=25°C)	150	50	750	2 ～ 7	5	2 A				t_{stg} < 11μs t_f < 1 μs						268	水平偏向用
〃 1391	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	80W (Tc=25°C)	150	100	750	5 ～ 15	10	4 A				t_{stg} < 14μs t_f < 1 μs						365	水平偏向用
〃 1392	日電	PA	Si. E	60±10	60±10	5 A	30W (Tc=25°C)	150	1	40	8000	2	2 A			t_{on} = 1 μs, t_f = 2 μs t_{stg} = 7 μs							370	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1393	三洋	SW	Si. EP	50	50	1.5A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	4000	3	800			t_{on} < 1.5μs, t_f < 4.5μs t_{stg} < 12μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1394	〃	〃	〃	50	50	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	4000	3	1.5A	5	−1.5A	t_{on} = 0.5μs, t_f = 1.5μs t_{stg} = 4 μs				20 *			268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1395	〃	〃	〃	50	50	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	4000	3	2.5A	5	−2.5A	t_{on} = 0.6μs, t_f = 1.5μs t_{stg} = 4 μs				20 *			268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 1396	三洋	SW	Si. TP	1500	800	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	> 8	5	500	10	−500		t_f < 0.7μs			8 *			346	水平偏向用
〃 1397	〃	〃	〃	1500	800	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	> 8	5	500	10	−500		t_f < 0.7μs			3 *			346	水平偏向用 ダンパ内蔵
〃 1398	〃	〃	〃	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	> 8	5	1 A	10	−1A		t_f < 0.7μs			3 *			346	水平偏向用 ダンパ内蔵
〃 1399	〃	〃	〃	1500	800	6 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	> 8	5	1 A	10	−1A		t_f < 0.7μs			3 *			346	水平偏向用 ダンパ内蔵
〃 1400	〃	〃	〃	1500	800	2.5A	80W (Tc=25°C)	150	10	800	25	5	500	10	−500	t_f < 0.7μs				3 *			346	水平偏向用
〃 1401	〃	〃	〃	1500	800	3.5A	80W (Tc=25°C)	150	10	800	25	5	500	10	−500	t_f < 0.7μs				3 *			346	水平偏向用
〃 1402	〃	〃	〃	1500	800	5 A	120W (Tc=25°C)	150	10	800	25	5	500	10	−500	t_f < 0.7μs				3 *			346	水平偏向用
〃 1403	〃	〃	〃	1500	800	6 A	120W (Tc=25°C)	150	10	800	25	5	500	10	−500	t_f < 0.7μs				3 *			346	水平偏向用
〃 1404	東芝	〃	Si. T	300	150	7 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	20	1.5	5 A			t_f < 1 μs							381	水平偏向用
〃 1405	〃	PA	〃	50	50	3 A	20W (Tc=25°C)	150	100	50	500	5	500										381	
〃 1406	〃	〃	〃	60	60	3 A	20W (Tc=25°C)	150	100	60	150	5	500										381	2SB1015 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1407	東芝	PA	Si. T	100	100	5 A	25W (Tc=25°C)	150	100	100	100	5	1 A										381	2SB1016 とコンプリ
〃 1408	〃	〃	〃	80	80	4 A	20W (Tc=25°C)	150	30	80	100	5	1 A										381	2SB1017 とコンプリ
〃 1409	〃	PA. SW	〃	600	400	6 A	25W (Tc=25°C)	150	500	600	1000	2	2 A			t_{on}< 3 μs, t_f<15μs t_{stg}<25μs							381	ダーリントン
〃 1410	〃	〃	〃	300	250	6 A	25W (Tc=25°C)	150	500	300	4000	2	2 A			t_{on}< 3 μs, t_f<15μs t_{stg}<25μs							381	ダーリントン
〃 1411	〃	〃	〃	100	80	7 A	25W (Tc=25°C)	150	5	100	70	1	1 A			t_{on}<1.2μs, t_f<1.5μs t_{stg}<7.5μs							381	
〃 1412	〃	〃	〃	70	50	7 A	25W (Tc=25°C)	150	30	70	120	1	1 A			t_{on}<0.6μs, t_f<1.5μs t_{stg}<7.5μs							381	
〃 1413	〃	〃	〃	60	40	3 A	25W (Tc=25°C)	150	20	60	5000	2	1 A			t_{on}<0.2μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs							381	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1414	〃	〃	〃	100	80	4 A	30W (Tc=25°C)	150	20	100	4000	2	1 A			t_{on}<0.2μs, t_f<1.5μs t_{stg}< 4 μs							381	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1415	〃	〃	〃	100	100	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	6000	3	3 A			t_{on}<2.5μs, t_f< 5 μs t_{stg}<12μs							381	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1416	〃	〃	〃	80	80	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	6000	3	3 A			t_{on}<2.5μs, t_f< 5 μs t_{stg}<12μs							381	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1417	〃	〃	〃	60	60	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	6000	3	3 A			t_{on}<2.5μs, t_f< 5 μs t_{stg}<12μs							381	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1418	日立	AF. PA	Si. E	120	80	1 A	1 W (プリント基板使用)	150	10	100	170	5	100	5	−150					140*	12		336	2SB1025 とコンプリ
〃 1419	〃	〃	〃	120	100	1 A	1 W (プリント基板使用)	150	10	100	130	5	100	5	−150					140*	12		336	2SB1026 とコンプリ
〃 1420	〃	〃	〃	180	120	1.5A	500	150	10	160	150	5	100										336	2SB1027 とコンプリ
〃 1421	〃	〃	〃	180	160	1.5A	500	150	10	160	130	5	100										336	2SB1028 とコンプリ
〃 1422	〃	〃	〃	100	60	2 A	500	150	0.1	80	130	5	100										336	2SB1029 とコンプリ
〃 1423	松下	AF	Si. EP	30	25	500	300	125	0.1	20	200	10	150										376	
〃 1424	〃	〃	〃	50	40	50	300	125	1	20	1000	10	2										376	
〃 1425	東芝	SW	Si. TMe	1500	600	2.5A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	500			t_f< 1 μs							380	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 1426	〃	〃	〃	1500	600	3.5A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	500			t_f< 1 μs							380	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 1427	〃	〃	〃	1500	600	5 A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	1 A			t_f< 1 μs							380	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 1428	〃	〃	〃	1500	600	6 A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	1 A			t_f< 1 μs							380	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 1429	〃	〃	〃	1500	600	2.5A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	500			t_f< 1 μs							380	水平偏向用
〃 1430	〃	〃	〃	1500	600	3.5A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	500			t_f< 1 μs							380	水平偏向用
〃 1431	〃	〃	〃	1500	600	5 A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A			t_f< 1 μs							380	水平偏向用
〃 1432	〃	〃	〃	1500	600	6 A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A			t_f< 1 μs							380	水平偏向用
〃 1433	〃	〃	〃	1500	600	7 A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A			t_f< 1 μs							380	水平偏向用
★ 〃 1434	〃	〃	〃	1700	800	5 A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	1 A			t_f< 1 μs							380	水平偏向用
〃 1435	日立	PA	Si. E	100	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	5000	3	8 A										373	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1436	〃	〃	Si. T	120	120	10A	80W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	5 A										373	ダンパ内蔵 ダーリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1437	ローム	PA	Si.TP	80	60	3 A	40W (Tc=25°C)	150	10	60	120	5	1 A	5	−500					8 *	90		268	2SB1033 とコンプリ
〃 1438	東芝	PA. SW	Si. E	80	80	2 A	15W (Tc=25°C)	150	10	80	5000	2	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f<1.5μs t_{stg}<10μs							342	
〃 1439	松下	SW	Si.TMe	1500	1500S	3 A	50W (Tc=25°C)	150	50	750	8	10	2 A			t_{stg}<10μs t_f< 1 μs							365	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 1440	〃	〃	〃	1500	1500S	3 A	50W (Tc=25°C)	150	50	750	10	10	2.5A			t_{stg}<10μs t_f< 1 μs							365	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 1441	〃	〃	〃	1500	1500S	4 A	80W (Tc=25°C)	150	50	750	12	10	3 A			t_{stg}<10μs t_f< 1 μs							365	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 1442	〃	PA. SW	Si.TP	40	20	7 A	30W (Tc=25°C)	150	50	40	180	2	2 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 1 μs							268	
〃 1443	〃	〃	〃	40	20	10A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	200	2	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							268	2SB871 とコンプリ
〃 1444	〃	〃	〃	40	20	7 A	30W (Tc=25°C)	150	50	40	180	2	2 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 1 μs							364	
〃 1445	〃	〃	〃	40	20	10A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	200	2	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							364	
〃 1446	〃	〃	Si. T	500	400	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	350	2000	2	2 A										364	ダンパ内蔵 ダーリントン 水平偏向用
〃 1447	三菱	PA	Si. E	30	25	1 A	900	150	1	30	150	1	500							100 *			6	2SB1035 とコンプリ
〃 1448	日電	〃	〃	70	45	3 A	10W (Tc=25°C)	150	1	45	200	5	500	5	−100					60 *	40		186	
〃 1449	松下	LN	Si. EP	120	120	20	300	125	1	50	350	5	2			NF=1.5dB (5 V, 1 mA, 1 kHz)							376	
〃 1450	〃	AF	〃	25	20	500	300	125	0.1	25	400	2	500										376	
〃 1451	日立	SW	Si. T	1500	600	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	500	1500	12	5	300			t_f< 1 μs							373	水平偏向用
〃 1452	〃	〃	〃	1500	600	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	500	1500	10	5	300			t_f< 1 μs							373	水平偏向用
〃 1453	〃	〃	〃	1500	600	3 A	50W (Tc=25°C)	150	500	1500	10	5	300			t_f<0.8μs							373	水平偏向用
〃 1454	〃	〃	〃	1500	600	4 A	50W (Tc=25°C)	150	500	1500	12	5	1 A			t_f< 1 μs							373	水平偏向用
〃 1455	〃	〃	〃	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	500	1500	12	5	1 A			t_f< 1 μs							373	水平偏向用
〃 1456	〃	〃	〃	1500	600	6 A	50W (Tc=25°C)	150	500	1500	12	5	1 A			t_f< 1 μs							373	水平偏向用
〃 1457	松下	PA	Si. DJ	100	100	6 A	60W (Tc=25°C)	150	10	100	4000	4	1 A										82	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1458	〃	AF	Si. EP	60	50	700	1 W	150	0.1	20	1500	10	150										151	
〃 1459	三洋	PA	Si.TP	150	150	1.5A	30W (Tc=25°C)	175	10	120	70~200	10	500	5	−100					8 *			268	2SB1037 とコンプリ
〃 1460	東芝	PA. SW	Si. T	100	100	30A	200W (Tc=25°C)	150	100	100	4000	5	20A			t_{on}< 3 μs, t_f< 3 μs t_{stg}<20μs							102	
〃 1461	松下	PA	Si.TP	430	430	5 A	80W (Tc=25°C)	150	500	300	1000	5	5 A										365	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1462	日電	AF. PA	Si. E	20	16	2 A	600	150	0.1	20	400	2	100										185	
〃 1463	日立	AF	〃	120	100	50	1 W (プリント基板使用)	150	10	100	140	5	10	5	−10					140 *	3		336	2SB1045 とコンプリ
〃 1464	〃	〃	〃	180	160	50	1 W (プリント基板使用)	150	10	160	140	5	10	10	−10					140 *	3.5		336	2SB1046 とコンプリ
〃 1465	〃	PA	〃	120	120	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	100	120	2000～30000	3	1 A			t_{on}=0.5μs t_{off}= 2 μs							245	ダーリントン
〃 1466	〃	SW	Si. T	500	450	15A	100W (Tc=25°C)	150	50	400	>200	3	15A			t_{on}=1.5μs, t_f= 3 μs t_{stg}= 4 μs							373	ダンパ内蔵 ダーリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★ 2SD1467	日立																							
〃 1468	ローム	AF	Si.EP	30	15	1 A	400	125	0.5	20	120~560	3	100	5	−50					150*	15		138	
〃 1469	〃	〃	〃	30	15	1 A	600	125	0.5	20	120~560	3	100	5	−50					150*	15		235	
〃 1470	日立	〃	Si.E	60	60	1 A	500	150	10	60	5000	3	500										336	ダーリントン
〃 1471	〃	〃	〃	40	30	300	500	150	1	30	25000	5	10										336	ダーリントン
〃 1472	〃	〃	〃	120	120	1.5A	500	150	100	120	5000	3	1 A										336	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1473	〃	〃	Si.T	500	400	500	500	150	20	400	20	5	250										336	
〃 1474	松下	PA	Si.EP	100	60	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	800	4	1 A										364	
〃 1475	〃	〃	Si.TP	80	60	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	80	4	1 A										364	
〃 1476	〃	〃	〃	80	60	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	80	4	1 A										268	
〃 1477	〃	AF	Si.EP	30	25	100	400	150	0.1	10	300	10	2										151	
〃 1478	〃	〃	〃	30	25	500	200	125	0.1	10	10000	10	500										176	ダーリントン
〃 1479	〃	SW	Si.TMe	1500	700	2 A	80W (Tc=25°C)	150	50	750	4	5	2 A			t_{stg}< 9 μs t_f< 1 μs							365	
〃 1480	〃	PA	Si.TP	60	60	2 A	25W (Tc=25°C)	150	200	60	100	4	1 A										364	2SB1052とコンプリ
〃 1481	日電	PA.SW	Si.E	60±10	60±10	2 A	15W (Tc=25°C)	150	1	40	2000~20000	2	1 A			t_{on}=0.5μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 2 μs							268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1482	松下	AF	Si.EP	40	40	100	200	125	0.1	40	150	10	5										176	
〃 1483	〃	〃	〃	20	20	700	1 W	150	1	20	1500	10	150										336	
〃 1484	ローム	〃	〃	50	50	500	200	125	0.5	30	180	3	100										335	
〃 1485	松下	PA	Si.TP	100	100	5 A	60W (Tc=25°C)	150	50	100	100	5	1 A										82	2SB1054とコンプリ
〃 1486	〃	〃	〃	120	120	6 A	70W (Tc=25°C)	150	50	120	100	5	1 A										82	2SB1055とコンプリ
〃 1487	〃	〃	〃	140	140	7 A	80W (Tc=25°C)	150	50	140	100	5	1 A										82	2SB1056とコンプリ
〃 1488	〃	〃	〃	150	150	9 A	100W (Tc=25°C)	150	50	150	100	5	1 A										82	2SD1057とコンプリ
〃 1489	日立	AF	Si.E	20	16	2 A	750	150	2	16	280	2	100	2	−10					80*	20		138	2SB1058とコンプリ
〃 1490	〃	〃	〃	70	50	1 A	750	150	0.2	25	230	2	100	2	−10					80*	20		138	2SB1059とコンプリ
〃 1491	日電	PA.SW	〃	60±10	60±10	±2A	10W (Tc=25°C)	150	10	40	8000	2	1 A			t_{on}=0.5μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 3 μs							225	ダンパ内蔵ダーリントン
★ 〃 1492	日立	SW	Si.T	1500	600	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	100	1200	15	5	300			t_f< 1 μs							373	水平偏向用
〃 1493	〃	〃	〃	1500	800	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	100	1200	12	5	300			t_f< 1 μs							373	水平偏向用
〃 1494	〃	〃	〃	1500	800	3 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1200	12	5	300			t_f< 1 μs							373	水平偏向用
★ 〃 1495	〃	〃	〃	1500	600	4 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1200	12	5	300			t_f< 1 μs							373	水平偏向用
〃 1496	〃	〃	〃	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1200	12	5	300			t_f< 1 μs							373	水平偏向用

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1497	日立	SW	Si. T	1500	650	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1200	15	5	300			t_f< 1 μs							373	水平偏向用
★ 〃 1498	〃	〃	〃	1400	650	8 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1000	12	5	300			t_f< 1 μs							373	水平偏向用
〃 1499	松下	PA	Si. TP	100	100	5 A	40W (Tc=25°C)	150	50	100	100	5	1 A										364	
〃 1500	東芝	AF. PA	Si. E	150	100	10A	40W (Tc=25°C)	150	10	150	5000	2	10A			t_{on}<1.5μs, t_f< 3 μs t_{stg}<10μs							268	ダンパ内蔵 ダーリントン
★ 〃 1501	日立	AF	〃	70	50	1 A	1 W	150	0.2	55	250	2	100										379	
〃 1502	日電	PA	Si. T	300	300	300	15W (Tc=25°C)	150	10	30	7000	1.5	100	1.5	−20					15 *	25		268	ダーリントン
〃 1503	日立	SW	〃	900	400	6 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	5	5	4 A			t_f<0.5μs							373	水平偏向用
〃 1504	〃	AF. PA	Si. E	30	15	500	300	150	1	20	430	1	150							300 *			378	
〃 1505	ローム	〃	Si. EP	60	50	3 A	30W (Tc=25°C)	150	1	40	120	3	500	5	−500					90 *	40		268	2SB1064 とコンプリ
〃 1506	〃	〃	〃	60	50	3 A	10W (Tc=25°C)	150	1	40	120	3	500								40		74	2SB1065 とコンプリ
〃 1507	〃	〃	〃	50	50	3 A	1 W	150	1	40	120	3	500								40		383	
〃 1508	東芝	AF.PA.SW	Si. E	30	30	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	30	7000	2	150			t_{on}<0.4μs, t_f<0.6μs t_{stg}<1.2μs							384	ダーリントン
〃 1509	〃	〃	〃	80	80	2 A	1.5W	150	10	80	5000	2	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f<1.5μs t_{stg}<10μs							384	ダーリントン
〃 1510	松下	AF. PA	Si. TP	60	60	4 A	35W (Tc=25°C)	150	100	60	5000	4	2 A										364	ダーリントン
〃 1511	〃	AF	Si. EP	60	50	1 A	1 W	150	0.1	25	15000	10	1 A										336	ダーリントン
〃 1512	〃	〃	〃	100	100	20	300	125	0.1	50	1000	10	2										376	
〃 1513	日電	PA	Si. E	20	16	2 A	750	150	0.1	16	350	2	100	10	−50					200 *	28		138	2SB1068 とコンプリ
★ 〃 1514	新電元	SW	Si. TP	100	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	4000	3	10A			t_{on}< 2 μs, t_f< 7 μs t_{stg}<15μs							119	ダーリントン
★ 〃 1515	〃	〃	〃	200	200	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	200	3000	3	10A			t_{on}< 2 μs, t_f< 7 μs t_{stg}<15μs							119	ダーリントン
〃 1516	松下	AF.PA.SW	Si. EP	130	80	2 A	25W (Tc=25°C)	150	10	100	130	2	500			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 4 μs							268	
〃 1517	〃	〃	〃	130	80	2 A	25W (Tc=25°C)	150	10	100	130	2	500			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 4 μs							364	
〃 1518	東芝	SW	Si. TMe	900	400	6 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	900	20	5	600			t_{on}<3.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<3.5μs							203	
〃 1519	〃	〃	〃	1400	600	10A	80W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	2 A			t_f< 1 μs							380	水平偏向用
〃 1520	日立	AF. PA	Si. T	100	80	4 A	20W (Tc=25°C)	150	100	80	3000	3	2 A										245	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1521	〃	〃	Si. E	50	50	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} 10	50	4000	3	1 A										160	ダンパ内蔵 ダーリントン
★ 〃 1522	〃	〃	Si. T	500	450	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	500	500	3	5 A										373	ダンパ内蔵 ダーリントン
★ 〃 1523	〃	〃	〃	450	450	15A	100W (Tc=25°C)	150	5	450	500	3	8 A										373	ダーリントン
★ 〃 1524	〃	〃	〃	450	450	10A	100W (Tc=25°C)	150	5	450	300	3	5 A										373	ダーリントン
〃 1525	東芝	AF.PA.SW	〃	100	100	30A	150W (Tc=25°C)	150	100	100	4000	5	20A			t_{on}< 3 μs, t_f< 3 μs t_{stg}<20μs							152	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1526	松下	AF. PA	Si. EP	130	40	1 A	1 W	150	0.1	20	200	2	500										151	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1527	日立	AF. PA	Si. T	1000	1000	500	25W (Tc=25°C)	150	10	800	20	5	10										268	
〃 1528	松下	SW	Si. EP	130	80	3 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	180	2	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.35μs t_{stg}<1.3μs							268	
〃 1529	〃	〃	〃	130	80	3 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	180	2	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.35μs t_{stg}<1.3μs							363	
〃 1530	〃	〃	〃	130	80	3 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	180	2	1 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.35μs t_{stg}<1.3μs							364	
〃 1531	〃	AF. PA	〃	50	40	2 A	1.2W	150	1	20	200	5	1 A										222	
〃 1532	サンケン	PA	Si. TP	120	100	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	120	3000	4	2 A										298	ダーリントン
〃 1533	松下	SW	〃	500	400	7 A	45W (Tc=25°C)	150	100	500	800	2	6 A			t_{on}< 2 μs, t_f< 9 μs t_{stg}< 8 μs							268	ダーリントン
〃 1534	〃	〃	〃	500	400	7 A	45W (Tc=25°C)	150	100	500	800	2	7 A			t_{on}< 2 μs, t_f< 9 μs t_{stg}< 8 μs							363	ダーリントン
〃 1535	〃	〃	〃	500	400	7 A	45W (Tc=25°C)	150	100	500	800	2	7 A			t_{on}< 2 μs, t_f< 9 μs t_{stg}< 8 μs							364	ダーリントン
〃 1536	ローム	AF	Si. EP	40	40	2 A	1 W	135	1	24	20000	3	500	6	−100					150*	11		360	ダーリントン
〃 1537	松下	AF. PA	〃	40	20	3 A	25W (Tc=25°C)	150	50	40	120	2	1 A										268	
〃 1538	〃	〃	〃	40	20	3 A	25W (Tc=25°C)	150	50	40	120	2	1 A										363	
〃 1539	〃	〃	〃	40	20	3 A	25W (Tc=25°C)	150	50	40	120	2	1 A										364	
〃 1540	東芝	〃	Si. T	100	60	6 A	60W (Tc=25°C)	150	100	100	800	5	500										102	
〃 1541	松下	SW	Si.TMe	1500	1500S	3 A	50W (Tc=25°C)	130	50	750	8	10	2 A			t_{stg}<10μs t_f< 1 μs							82	水平偏向用
〃 1542	東芝	〃	〃	1500	600	1.5A	40W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	500			t_f< 1 μs							382	水平偏向用
〃 1543	〃	〃	〃	1500	600	2.5A	40W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	500			t_f< 1 μs							382	水平偏向用
〃 1544	〃	〃	〃	1500	600	3.5A	40W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	500			t_f< 1 μs							382	水平偏向用
〃 1545	〃	〃	〃	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A			t_f< 1 μs							382	水平偏向用
〃 1546	〃	〃	〃	1500	600	6 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A			t_f< 1 μs							382	水平偏向用
〃 1547	〃	〃	〃	1500	600	7 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	5	1 A			t_f< 1 μs							382	水平偏向用
〃 1548	〃	〃	〃	1500	600	10A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	22	5	2 A			t_f< 1 μs							382	水平偏向用
★ 〃 1549	〃	〃	〃	1000	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	15	5	1 A			t_f< 1 μs							382	水平偏向用
★ 〃 1550	〃	〃	〃	1000	400	10A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	100			t_f< 1 μs							382	水平偏向用
★ 〃 1551	〃	〃	〃	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	5	5	4.5A			t_f< 1 μs							382	水平偏向用
★ 〃 1552	〃	〃	〃	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	5	5	4.5A			t_f< 1 μs							382	水平偏向用
〃 1553	〃	〃	〃	1500	600	2.5A	40W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	500										382	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 1554	〃	〃	〃	1500	600	3.5A	40W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	500										382	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 1555	〃	〃	〃	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	500			t_f< 1 μs							382	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 1556	〃	〃	〃	1500	600	6 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	12	5	1 A			t_f< 1 μs							382	ダンパ内蔵 水平偏向用

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1557	日電	PA	Si.T	200	150	2 A	20W (Tc=25°C)	150	50	150	100	10	400	10	−400					10 *			186	
〃 1558	日立	AF	〃	60	60	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	60	5000	3	2 A										268	ダーリントン
〃 1559	〃	AF. PA	〃	100	100	20A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	5000	3	10A										373	ダンパ内蔵ダーリントン
★ 〃 1560																								
★ 〃 1561																								
〃 1562	ローム	AF. PA	Si.EP	120	120	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	100	120	5	100	5	−100					80 *	20		268	2SB1085とコンプリ ○
〃 1563	〃	〃	〃	120	120	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	1	100	120	5	100	5	−100					60 *	20		74	2SB1086とコンプリ
〃 1564	日電	PA. SW	Si. E	60±10	60±10	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	40	2000～20000	2	2 A			t_{on}= 1 μs, t_f= 2 μs t_{stg}= 7 μs							268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1565	〃	〃	〃	100	100	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	8000	2	2 A			t_{on}= 1 μs, t_f=1.2μs t_{stg}=3.5μs							268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1566	〃	PA. SW	〃	150	100	±10A	60W (Tc=25°C)	150	10	100	9000	2	10A			t_{on}< 1 μs, t_f< 2 μs t_{stg}< 5 μs							370	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1567	〃	PA	Si. T	60	60	3 A	30W (Tc=25°C)	150	10	60	100	5	500	5	−100					16 *	48		268	
〃 1568	〃	〃	〃	100	100	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	100	5	500	5	−100					20 *			268	2SB1090とコンプリ
〃 1569	〃	〃	Si. E	60	60	3 A	30W (Tc=25°C)	150	10	60	1300	5	500	5	−100	$V_{CE(sat)}$<0.5V (I_C= 2 A, I_B=20mA) $V_{BE(sat)}$<1.2V				100 *	60		268	
★ 〃 1570																								
〃 1571	東芝	SW	Si.TMe	800	400	3 A	2 W	150	1 mA	800	20	5	500	t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 7 μs									381	
〃 1572	日立	AF. PA	Si. T	60	60	8 A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	5000	3	4 A	$V_{CE(sat)}$<1.5V (I_C= 4 A, I_B= 8 mA) $V_{BE(sat)}$< 2 V									268	ダーリントン
★ 〃 1573	〃	AF	〃	600	600	100	1 W	150	20	500	100	20	20	$V_{CE(sat)}$< 1 V (I_C=50mA, I_B=10mA) $V_{BE(sat)}$<1.5V									379	
〃 1574	松下	AF. PA	Si.EP	100	80	1 A	10W (Tc=25°C)	150	0.1	25	4000～40000	10	1 A	$V_{CE(sat)}$<1.8V $V_{BE(sat)}$<1.2V									361	
〃 1575	〃	SW	Si.TMe	1500	1500S	2.5A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	1500	4	10	2 A	t_{stg}< 9 μs t_f< 1 μs									364	水平偏向用
〃 1576	〃	〃	〃	1500	700	2.5A	80W (Tc=25°C)	150	50	750	4	5	2 A	t_{stg}< 9 μs t_f< 1 μs									82	水平偏向用
〃 1577	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	1500	8	10	4 A	t_{stg}<15μs t_f< 1 μs									82	水平偏向用
★ 〃 1578	日立	AF	Si. E	30	15	700	500	150	1	20	550	1	150	1	−50					300 *			379	
〃 1579	日電	AF.PA.SW	〃	150	80	±1.5A	1 W	150	0.5	100	2000～30000	2	1 A	t_{on}< 1 μs, t_f< 2 μs t_{stg}< 2 μs									278	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1580	ローム	AF. PA	Si.TP	100	80	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	80	100	1	1 A	5	−500					5 *	150		268	
〃 1581	日電	〃	Si. E	30	25	2 A	1 W	150	0.1	30	800～3200	5	500	10	−500					350 *	26		278	
〃 1582	〃	〃	〃	60	50	1 A	1 W	150	0.1	60	800～3200	5	300	10	−500					250 *	18		278	
〃 1583	〃	PA. SW	〃	30	20	2 A	10W (Tc=25°C)	150	10	20	2000	5	500	5	−100	t_{on}=0.6μs, t_f=0.3μs t_{stg}=1.5μs				270 *	20		186	
〃 1584	〃	〃	〃	60	60	3 A	10W (Tc=25°C)	150	10	60	1800	5	500	5	−100	t_{on}=0.9μs, t_f= 1 μs t_{stg}=2.6μs				120 *	20		186	
〃 1585	〃	PA	Si. T	60	60	3 A	15W (Tc=25°C)	150	10	60	100	5	500	5	−100					16 *	48		96	2SB1094とコンプリ
〃 1586	〃	〃	〃	100	100	4 A	20W (Tc=25°C)	150	10	100	100	5	500	5	−100					20 *			96	2SB1095とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SD1587	日電	PA	Si. T	200	150	2 A	25W (Tc=25°C)	150	50	150	90	10	400	10	−400					5 *			96	2SB1096 とコンプリ
〃 1588	〃	SW. PA	Si. E	100	60	7 A	30W (Tc=25°C)	150	1	80	40~200	1	3 A										96	2SB1097 とコンプリ
〃 1589	〃	PA. SW	〃	100	100	±5A	20W (Tc=25°C)	150	1	100	8000	2	2 A			t_{on}= 1 μs, t_f=1.2μs t_{stg}=3.5μs							96	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1590	〃	〃	〃	150	100	+8A −5A	25W (Tc=25°C)	150	1	100	2000~15000	2	3 A			〃							96	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1591	〃	〃	〃	150	100	±10A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	6000	2	10A			t_{on}= 1 μs, t_f= 2 μs t_{stg}= 5 μs							96	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1592	〃	PA	Si. T	500	300	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	400	1000	2	2 A										96	ダーリントン
〃 1593	〃	〃	Si. E	60	60	3 A	20W (Tc=25°C)	150	10	60	1300	5	500	5	−100					110 *	50		96	
〃 1594	〃	〃	〃	100	100	6 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	1300	5	1 A	5	−100					110 *	100		96	
〃 1595	〃	PA. SW	〃	60±10	60±10	5 A	20W (Tc=25°C)	150	0.5	40	6000	2	2 A										96	ダンパ内蔵 ダーリントン
★ 〃 1596																								
〃 1597	日立	SW	Si. T	120	120	30A	80W (Tc=25°C)	150	10	100	5000	2	15A			t_{on}< 2 μs, t_{off}<12μs t_{stg}<10μs							373	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1598	日電	PA	Si. E	60	60	1 A	10W (Tc=25°C)	150	10	50	8000	2	500										185	ダーリントン
〃 1599	日立	AF. PA	Si. T	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	5000	3	2 A			t_{on}=0.5μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 6 μs							268	ダーリントン
〃 1600	〃	〃	〃	80	80	8 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	5000	3	4 A			t_{on}=0.5μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 6 μs							268	ダーリントン
〃 1601	〃	〃	〃	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	5000	3	2 A			t_{on}= 1 μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 6 μs							268	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1602	〃	〃	〃	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	5000	3	2 A			t_{on}= 1 μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 6 μs							268	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1603	〃	〃	〃	60	60	8 A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	5000	3	4 A			t_{on}=0.5μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 5 μs							268	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1604	〃	〃	〃	80	80	8 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	5000	3	4 A			t_{on}=0.5μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 5 μs							268	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1605	〃	〃	〃	120	120	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	1.5A			t_{on}=0.7μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 7 μs							268	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1606	〃	〃	〃	120	120	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	3 A			t_{on}=0.6μs, t_f= 2 μs t_{stg}= 7 μs							268	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1607	〃	〃	〃	120	120	10A	40W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	5 A										268	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1608	松下	〃	Si. TP	120	120	8 A	50W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	4 A										364	ダーリントン
〃 1609	日立	〃	Si. E	160	160	100	1.25W	150	10	160	140	5	10	5	−10					140 *	3.8		160	2SB1109 とコンプリ
〃 1610	〃	〃	〃	200	200	100	1.25W	150	10	160	140	5	10	5	−10					140 *	3.8		160	2SB1110 とコンプリ
〃 1611	松下	〃	Si. TP	500	400	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	350	33000	2	2 A										363	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1612	日立	〃	Si. E	120	120	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	3 A										390	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1613	〃	〃	Si. T	120	120	8 A	40W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	4 A										390	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1614	日電	〃	Si. E	40	20	2 A	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	30	350	2	100	10	−50					200 *	28		336	2SB1114 とコンプリ
〃 1615	〃	〃	〃	60	50	1 A	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	60	290	2	100	2	−100					160 *	19		336	2SB1115 とコンプリ ○
〃 1616	〃	PA. SW	〃	60	50	1 A	750	150	0.1	60	135~600	2	100	2	−100					160 *	19		138	2SB1116 とコンプリ ○

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1617	日電	PA. SW	Si. E	40	25	3 A	1 W	150	0.1	40	300	2	1 A	5	−100	t_{on}=70ns, t_f=60ns t_{stg}=420ns				200 *	40		278	2SB1117とコンプリ
〃 1618	三洋	AF	Si. EP	20	15	700	500	150	1	15	350	2	50										336	
〃 1619	〃	〃	〃	25	25	1 A	500	150	1	20	150	2	50										336	
〃 1620	〃	〃	〃	30	10	3 A	500	150	1	20	210	2	3 A										336	
〃 1621	〃	〃	〃	30	25	2 A	500	150	0.1	20	180	2	100										336	
〃 1622	〃	〃	〃	60	50	1 A	500	150	1	50	150	2	50										336	
〃 1623	〃	〃	〃	60	50	2 A	500	150	0.1	50	200	2	100										336	
〃 1624	〃	〃	〃	60	50	3 A	500	150	1	40	200	2	100										336	
〃 1625	〃	〃	〃	80	50	700	500	150	0.1	40	25000	2	50										336	
〃 1626	〃	〃	〃	80	50	1.5A	500	150	0.1	40	25000	2	500										336	
〃 1627	〃	〃	〃	30	25	2 A	500	150	1	20	25000	2	500										336	
〃 1628	〃	〃	〃	60	20	5 A	500	150	1	50	230	2	500										336	
〃 1629	日電	PA. SW	Si. E	60±10	60±10	±1.2A	10W (Tc=25°C)	150	0.5	40	2000〜30000	2	500			t_{on}=0.5μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 3 μs							268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1630	〃	AF. PA	〃	60±10	60±10	±1A	10W (Tc=25°C)	150	0.5	40	>2000	2	500										225	〃
〃 1631	東芝	SW	〃	30	30	1.5A	1 W	150	10	30	7000	2	150										387	ダーリントン
〃 1632	松下	〃	Si. TMe	1500	1500S	4 A	80W (Tc=25°C)	150	50	750	10	10	3 A			t_{stg}<10μs t_f<0.8μs							82	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1633	〃	AF. PA	〃	100	100	5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	100	6000	3	3 A			t_{on}< 3 μs, t_f< 3 μs t_{stg}< 5 μs							364	ダーリントン
〃 1634	〃	〃	〃	100	100	8 A	50W (Tc=25°C)	150	100	100	6000	3	5 A			〃							364	〃
〃 1635	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	100W (Tc=25°C)	150	100	750	100	10	3.5A										102	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1636	〃	〃	〃	300	300S	70	1 W	150	2	12	30〜220	10	5	10	−10					80 *	4		151	
〃 1637	ローム	〃	Si. EP	60±10	60±10	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	40	10000	2	1 A										74	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1638	〃	〃	〃	100	100	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	80	10000	2	1 A										74	ダンパ内蔵
〃 1639	三菱	〃	〃	100	80	2.2A	10W (Tc=25°C)	200	0.5	50	40〜200	5	100								<100		84B	
〃 1640	松下	〃	Si. E	120	100	2 A	1.2W	150	1	25	4000〜40000	10	1 A										222	
〃 1641	〃	〃	Si. TP	55^{+15}_{-10}	55^{+15}_{-10}	4 A	80W (Tc=25°C)	150	100	45	1000	5	500	コレクタ回路に直列抵抗. CB端子間にZ.D.									365	
〃 1642	日立	AF	Si. E	100	60	2 A	700	150	1	65	200	1	200										138	
〃 1643	松下	AF. PA	Si. TP	80	60	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	1000	4	500										82	
〃 1644	〃	PA	Si. EP	95±10	95±10	1 A	1 W (プリント板つき)	150	0.1	25	10000	10	1 A										336	
〃 1645	〃	〃	〃	60±10	60±10	1 A	1.2W	150	0.1	25	20000	10	1 A										222	
〃 1646	ローム	AF. PA	〃	100	100	2 A	25W (Tc=25°C)	150	10	80	10000	2	1 A								25		268	ダンパ内蔵ダーリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1647	ローム	AF. PA	Si. EP	50	50	2 A	25W (Tc=25°C)	150	10	40	10000	2	1 A								25		268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1648	三洋	AF	〃	30	20	20	150	150	1	20	250	5	1	コレクタ回路直列抵抗 100Ω									176B	
〃 1649	〃	SW	Si. TP	1500	800	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	500	10	−500	t_f<0.4μs				3 *			397	ダンパ内蔵水平偏向用
〃 1650	〃	〃	〃	1500	800	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	500	10	−500	〃				3 *			397	〃
〃 1651	〃	〃	〃	1500	800	5 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A	10	−1A	〃				3 *			397	〃
〃 1652	〃	〃	〃	1500	800	6 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A	10	−1A	〃				3 *			397	〃
〃 1653	〃	〃	〃	1500	800	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	500	10	−500	〃				3 *			397	水平偏向用
〃 1654	〃	〃	〃	1500	800	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	500	10	−500	〃				3 *			397	〃
〃 1655	〃	〃	〃	1500	800	5 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A	10	−1A	〃				3 *			397	〃
〃 1656	〃	〃	〃	1500	800	6 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A	10	−1A	〃				3 *			397	〃
〃 1657	松下	AF	Si. EP	25	15	700	600	150	1	20	500	1	150	10	−50					150 *	12		138	
〃 1658	東芝	PA. SW	Si. E	50	50	2 A	10W (Tc=25°C)	150	10	40	5000	2	1 A			t_{on}<1.2μs, t_f<1.8μs t_{stg}<12μs							384	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1659	日電	AF. PA. SW	〃	150	60	±1.5A	1 W	150	10	80	10000	2	1 A										278	〃
〃 1660	ローム	AF. PA	Si. EP	100	100	1.5A	1 W	135	1	80	10000	2	1 A										383	〃
〃 1661	〃	〃	〃	50	50	1.5A	1 W	135	1	40	10000	2	1 A										383	〃
〃 1662	東芝	AF. PA. SW	Si. T	100	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	5000	3	15A			t_{on}<2.1μs, t_f<7.5μs t_{stg}<25μs							203	〃
〃 1663	松下	SW	Si. TMe	1500	1500S	5 A	80W (Tc=25°C)	150	50	750	35	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							82	
〃 1664	ローム	AF. PA	Si. EP	40	32	1 A	500	135	0.5	20	180	3	100	5	−50					150 *	15		336	
〃 1665	〃	〃	〃	120	120	1.5A	1 W	135	1	100	180	5	100	5	−100					80 *	20		383	
〃 1666	三洋	PA	〃	60	60	3 A	20W (Tc=25°C)	150	100	20	150	2	1 A										388	
〃 1667	〃	〃	〃	60	50	5 A	20W (Tc=25°C)	150	100	40	150	2	1 A										388	
〃 1668	〃	〃	〃	60	50	7 A	25W (Tc=25°C)	150	100	40	150	2	1 A	5	−1A					10 *			388	2SB1135とコンプリ
〃 1669	〃	〃	〃	60	50	12A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	150	2	1 A										388	
〃 1670	日電	SW	Si. E	150	100	±10A	65W (Tc=25°C)	150	10	100	9000	2	10A			t_{on}= 1 μs, t_f= 2 μs t_{stg}= 5 μs							404	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1671	〃	〃	〃	150	100	±15A	70W (Tc=25°C)	150	10	100	3500	2	15A			〃							404	〃
〃 1672	〃	〃	〃	150	100	+25A −15A	70W (Tc=25°C)	150	10	100	3500	2	15A			〃							404	〃
〃 1673	〃	PA	Si. T	500	400	10A	70W (Tc=25°C)	150	100	400	600	2	2 A										404	〃
★ 〃 1674																								
★ 〃 1675																								
〃 1676	日立	AF	Si. EP	20	20	600	300	150	0.2	16	100	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=6.8kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)		t_{on}=0.3μs, t_f=0.7μs t_{stg}=1.5μs							378	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1677	三洋	SW	Si.TP	1500	800	5 A	100W (Tc=25°C)	150	10	800	18	5	500			t_f<0.5μs							346	
〃 1678	東芝	AF. PA. SW	Si.T	100	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	5000	3	15A			t_{on}<2.5μs, t_f< 5 μs t_{stg}<16μs							125	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1679	松下	AF. PA	Si.EP	18±5	18±5	500	200	150	0.1	5	400	2	500	CB間にZ. D.									176	
〃 1680	〃	〃	Si.TP	330	200	7 A	70W (Tc=25°C)	150	100	330	25	4	5 A										82	
〃 1681	三洋	PA	Si.EP	20	18	1.2A	1.3W	150	0.1	15	200	2	100										389	
〃 1682	〃	〃	〃	60	50	2.5A	1.3W	150	0.1	50	200	2	100										389	
〃 1683	〃	〃	〃	60	50	4 A	1.3W	150	1	40	200	2	100										389	
〃 1684	〃	〃	〃	120	100	1.5A	1.3W	150	0.1	100	200	5	100										389	
〃 1685	〃	〃	〃	60	20	5 A	1.3W	150	0.1	50	200	2	500										389	
〃 1686	日立	AF. PA	Si.T	120	120	3 A	20W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	1.5A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.1μs t_{stg}=4.5μs							391	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1687	〃	〃	〃	60	60	3 A	20W (Tc=25°C)	150	100	60	5000	3	1.5A										391	〃
〃 1688	〃	〃	〃	120	120	8 A	25W (Tc=25°C)	150	100	120	7000	3	4 A										391	〃
〃 1689	〃	〃	Si.E	120	120	6 A	25W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	3 A			t_{on}= 1 μs, t_f=0.7μs t_{stg}= 2 μs							391	〃
〃 1690	〃	〃	Si.T	120	120	8 A	25W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	4 A			t_{on}=0.4μs, t_f=1.1μs t_{stg}=5.4μs							391	〃
〃 1691	日電	PA. SW	Si.E	60	60	5 A	1.3W	150	10	50	100~400	1	2 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							225	2SB1151とコンプリ
〃 1692	〃	〃	〃	150	100	±3A	1.3W	150	10	100	2000~20000	2	1.5A			t_{on}=0.5μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 2 μs							225	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1693	〃	〃	〃	60±10	60±10	±3A	1.3W	150	10	40	2000~20000	2	1.5A			〃							225	〃
〃 1694	〃	〃	〃	60	60	3 A	1.3W	150	10	60	1500	5	500			t_{on}=0.9μs, t_f= 1 μs t_{stg}=2.6μs							225	
〃 1695	〃	〃	〃	31±4	31±4	±2A	1.3W	150	10	20	2000~20000	2	1 A			t_{on}=0.5μs, t_f= 1 μs t_{stg}= 3 μs							225	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1696	〃	〃	〃	31±4	31±4	±4A	1.3W	150	1	25	10000	2	2 A										225	〃
〃 1697	〃	AF. PA	〃	100	80	±800	1 W	150	1	80	10000	2	500										278	〃
〃 1698	〃	〃	〃	100	80	±800	750	150	1	80	10000	2	500										138	〃
〃 1699	〃	〃	〃	100	80	±800	400	150	1	80	10000	2	500										336	〃
〃 1700	〃	〃	〃	60±10	60±10	±800	1 W	150	1	40	10000	2	500										278	〃
〃 1701	〃	〃	〃	60±10	60±10	±800	750	150	1	40	10000	2	500										138	〃
〃 1702	〃	〃	〃	60±10	60±10	±800	400	150	1	40	10000	2	500										336	〃
〃 1703	松下	〃	Si.TP	160	160	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	160	130	5	1 A										365	
〃 1704	〃	〃	〃	170	170	15A	150W (Tc=25°C)	150	50	170	130	5	1 A										393	
〃 1705	〃	〃	Si.EP	130	80	10A	70W (Tc=25°C)	150	10	100	120	2	3 A										82	2SB1154とコンプリ
〃 1706	〃	〃	〃	130	80	15A	80W (Tc=25°C)	150	10	100	120	2	3 A										82	2SB1155とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SD1707	松下	AF. PA	Si. EP	130	80	20A	100W (Tc=25°C)	150	10	100	120	2	3 A										82	2SB1156 とコンプリ
〃 1708	東芝	AF. PA. SW	Si. E	120	120	2 A	1.5W	150	100	120	6000	2	1 A			t_{on}<1.2μs, t_f<1.8μs t_{stg}<12μs							384	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1709	三洋	SW	Si. TP	1500	800	5 A	100W (Tc=25°C)	150	10	800	25	5	500			t_f<0.5μs							346	ダンパ内蔵
〃 1710	〃	〃	〃	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	25	5	500			〃							397	
〃 1711	〃	〃	〃	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	25	5	500			〃							397	ダンパ内蔵
〃 1712	松下	AF. PA	〃	100	100	5 A	60W (Tc=25°C)	150	50	100	100	5	1 A										82	2SB1157 とコンプリ
〃 1713	〃	〃	〃	120	120	6 A	70W (Tc=25°C)	150	50	120	100	5	1 A										82	2SB1158 とコンプリ
〃 1714	〃	〃	〃	140	140	7 A	80W (Tc=25°C)	150	50	140	100	5	1 A										82	2SB1159 とコンプリ
〃 1715	〃	〃	〃	150	150	9 A	100W (Tc=25°C)	150	50	150	100	5	1 A										82	2SB1160 とコンプリ
〃 1716	〃	〃	〃	160	160	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	160	130	5	1 A										82	2SB1161 とコンプリ
〃 1717	〃	〃	〃	160	160	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	160	130	5	1 A										393	
〃 1718	〃	〃	〃	170	170	15A	150W (Tc=25°C)	150	50	170	130	5	1 A										393	
〃 1719	〃	〃	〃	100	60	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	800	4	1 A										363	
〃 1720	ローム	〃	〃	80	60	5 A	40W (Tc=25°C)	150	10	80	100	5	1 A	5	−500					8 *	130		268	
〃 1721	日電	〃	Si. E	60	50	2 A	1 W	150	0.1	60	300	2	100										278	
〃 1722	三洋	〃	Si. EP	60	50	5 A	20W (Tc=25°C)	150	1	40	200	2	500										398	
〃 1723	〃	〃	〃	60	50	8 A	20W (Tc=25°C)	150	1	40	200	2	500										398	
〃 1724	〃	〃	〃	120	100	3 A	20W (Tc=25°C)	150	1	100	200	5	500										398	
〃 1725	〃	〃	〃	120	100	4 A	20W (Tc=25°C)	150	1	100	200	5	500										398	
〃 1726	富士電機	SW	Si. TP	60	60	7 A	25W (Tc=25°C)	150	100	60	4000	1.5	3 A			t_{on}< 2 μs, t_f< 2 μs t_{stg}<15μs							402	ダーリントン
〃 1727	松下	〃	〃	1500	700	1.5A	60W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	500			t_f<0.8μs							365	ダンパ内蔵
〃 1728	〃	〃	〃	1500	700	2.5A	60W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	500			〃							365	〃
〃 1729	〃	〃	〃	1500	700	3.5A	60W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	500			〃							365	〃
〃 1730	〃	〃	〃	1500	700	5 A	100W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	1 A			〃							365	〃
〃 1731	〃	〃	〃	1500	700	6 A	100W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	1 A			〃							365	〃
〃 1732	〃	〃	〃	1500	700	7 A	120W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	1 A			〃							365	〃
〃 1733	ローム	AF. PA	Si. EP	120	80	1 A	15W (Tc=25°C)	150	1	100	180	3	100							100 *	20		403	
〃 1734	松下	SW	Si. TP	1500	700	1.5A	40W (Tc=25°C)	150	10	750	15	5	500			t_f<0.8μs							364	
〃 1735	〃	〃	〃	1500	700	1.5A	60W (Tc=25°C)	150	10	750	15	5	500			〃							82	
〃 1736	〃	〃	〃	1500	700	2.5A	60W (Tc=25°C)	150	10	750	15	5	500			〃							82	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1737	松下	SW	Si.TP	1500	700	3.5A	60W (Tc=25°C)	150	10	750	15	5	500			t_f<0.8μs							82	
〃 1738	〃	〃	〃	1500	700	5 A	100W (Tc=25°C)	150	10	750	15	5	500			〃							82	
〃 1739	〃	〃	〃	1500	700	6 A	100W (Tc=25°C)	150	10	750	15	5	1 A			〃							82	
〃 1740	富士電機	AF. PA	〃	150	100	5 A	25W (Tc=25°C)	150	1 mA	150	5000	4	1 A	5	−500					22 *	54		402	
〃 1741	松下	〃	〃	200	150	2 A	15W (Tc=25°C)	150	50	200	130	10	150										392	2SB1171 とコンプリ
〃 1742	〃	〃	〃	60	60	3 A	15W (Tc=25°C)	150	200	60	150	4	1 A										392	2SB1172 とコンプリ
〃 1743	〃	〃	〃	60	60	4 A	15W (Tc=25°C)	150	400	60	120	4	1 A										392	2SB1173 とコンプリ
〃 1744	〃	〃	Si.EP	130	80	3 A	15W (Tc=25°C)	150	10	100	150	2	500										392	2SB1174 とコンプリ
〃 1745	〃	〃	〃	130	80	4 A	15W (Tc=25°C)	150	10	100	150	2	1 A										392	2SB1175 とコンプリ
〃 1746	〃	〃	〃	130	80	5 A	15W (Tc=25°C)	150	10	100	150	2	2 A										392	2SB1176 とコンプリ
〃 1747	〃	〃	〃	130	80	7 A	15W (Tc=25°C)	150	10	100	150	2	3 A										392	2SB1177 とコンプリ
〃 1748	〃	〃	Si.TP	60	60	2 A	15W (Tc=25°C)	150	1 mA	60	5000	4	1 A										392	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1749	〃	〃	〃	60	60	4 A	15W (Tc=25°C)	150	200	60	5000	3	3 A										392	〃
〃 1750	〃	〃	〃	60	60	8 A	15W (Tc=25°C)	150	100	60	5000	3	4 A										392	〃
〃 1751	〃	〃	〃	60	60	2 A	15W (Tc=25°C)	150	200	60	100	4	1 A										392	2SB1170 とコンプリ
〃 1752	〃	〃	Si.EP	40	20	10A	15W (Tc=25°C)	150	50	40	150	2	3 A										392	
〃 1753	〃	〃	Si.TP	200	150	1 A	15W (Tc=25°C)	150	100	200	1000	4	200										392	
〃 1754	〃	〃	〃	80	60	3 A	15W (Tc=25°C)	150	100	80	1300	4	500										392	
〃 1755	〃	〃	Si.EP	100	60	6 A	15W (Tc=25°C)	150	100	100	1000	4	1 A										392	
〃 1756	日立	PA	Si.T	200	200	10A	40W (Tc=25°C)	150	I_{CEO} 500	180	5000	3	5 A										268	ダーリントン
〃 1757	ローム	AF	Si.EP	30	15	500	200	125	0.5	20	270	3	100										176	
〃 1758	〃	AF. PA	〃	40	32	2 A	15W (Tc=25°C)	150	1	20	180	3	500							100 *	50		403	
〃 1759	〃	〃	〃	40	40	2 A	15W (Tc=25°C)	150	1	24	20000	3	500								11		403	ダーリントン
〃 1760	〃	〃	〃	60	50	3 A	15W (Tc=25°C)	150	1	40	140	3	500							90 *	40		403	
〃 1761	〃	〃	〃	80	60	3 A	35W (Tc=25°C)	150	10	60	120	5	1 A	5	−500					8 *	90		405	2SB1187 とコンプリ
〃 1762	〃	〃	〃	60	50	3 A	25W (Tc=25°C)	150	1	40	120	3	500	5	−500					90 *	40		405	2SB1185 とコンプリ
〃 1763	〃	〃	〃	120	120	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	100	120	5	100	5	−100					80 *	20		405	2SB1186 とコンプリ
〃 1764	〃	〃	〃	60±10	60±10	2 A	20W (Tc=25°C)	150	10	40	2500	2	1 A								25		405	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1765	〃	〃	〃	100	100	2 A	20W (Tc=25°C)	150	10	100	2500	2	1 A								25		405	〃
〃 1766	〃	〃	〃	40	32	2 A	500	150	1	20	180	3	500										336	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ic(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SD1767	ローム	AF. PA	Si. EP	80	80	700	500	150	0.5	50	180	3	100	10	−50					120 *	10		336	
〃 1768	〃	〃	〃	100	80	1 A	300	135	1	80	180	3	500	10	−50					100 *	20		406	
〃 1769	サンケン	PA	Si. TP	120	120	6 A	50W (Tc=25°C)	150	10	120	5000	2	3 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1 μs t_{stg}=5.5μs							298	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1770	松下	AF. PA	〃	200	150	1 A	25W (Tc=25°C)	150	50	200	120	10	100										268	
〃 1771	〃	〃	〃	200	150	1 A	25W (Tc=25°C)	150	50	200	120	10	100										363	2SB1191とコンプリ
〃 1772	〃	〃	〃	200	150	1 A	25W (Tc=25°C)	150	50	200	120	10	100										364	
〃 1773	〃	〃	〃	120	120	8 A	50W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	4 A										364	ダーリントン
〃 1774	〃	〃	〃	80	60	2 A	25W (Tc=25°C)	150	100	80	1000	4	300										268	
〃 1775	〃	〃	〃	80	60	2 A	25W (Tc=25°C)	150	100	80	1000	4	300										363	
〃 1776	〃	〃	〃	80	60	2 A	25W (Tc=25°C)	150	100	80	1000	4	300										364	
〃 1777	日立	AF. SW	Si. E	20	20	600	150	150			100	5	10	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=6.8±2.04kΩ, R_B/R_{BE}=1.0±0.1)					t_{on}=0.3μs, t_f=0.7μs t_{stg}=1.5μs				408C	
〃 1778	ローム	AF. PA	Si. TP	80	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	60	120	5	1 A	5	−500					8 *	90		268	
〃 1779	日電	PA	Si. E	60	60	2 A	1 W	150	0.1	40	1500	5	1 A			t_{on}=0.8μs, t_f=1.2μs t_{stg}= 2 μs							278	
〃 1780	〃	〃	〃	60±10	60±10	2 A	1 W	150	0.1	40	1500	5	1 A										278	CB間にZD
〃 1781	ローム	AF. PA	Si. EP	40	32	800	200	125	0.5	20	180	3	100	10	−50					150 *	10		176	
〃 1782	〃	〃	〃	80	80	700	200	125	0.5	50	180	3	100	10	−50					120 *	10		176	
〃 1783	〃	〃	〃	50	50	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	40	5000	2	2 A								75		268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1784	東芝	AF.PA.SW	Si. E	30	30	1.5A	500	150	10	30	7000	2	150			t_{on}<0.4μs, t_f<0.6μs t_{stg}<1.2μs							336	ダーリントン
〃 1785	サンケン	PA	Si. TP	120	120	6 A	30W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	2	3 A										400	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1786	ローム	AF. PA	Si. EP	40	40	2 A	900	150	1	24	20000	3	500										294	ダーリントン
〃 1787	〃	AF	〃	50	50	500	400	125	0.5	30	180	3	100	5	−20					250 *	6.5		235	
〃 1788	新電元	SW	Si. TP	100	100	±4A	25W (Tc=25°C)	150	100	100	2500	3	1 A	10	−400	t_{on}< 2 μs, t_f< 5 μs t_{stg}<12μs				50 *			410	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1789	〃	〃	〃	200	200	±4A	25W (Tc=25°C)	150	100	200	2500	3	1 A	10	−400	〃				50 *			410	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1790	〃	〃	〃	60±10	60±10	±4A	25W (Tc=25°C)	150	100	40	2500	3	1 A	10	−400	〃				50 *			410	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1791	〃	〃	〃	100	100	7 A	30W (Tc=25°C)	150	100	100	5000	3	3 A	10	−700	〃				50 *			410	ダーリントン
〃 1792	〃	〃	〃	200	200	7 A	30W (Tc=25°C)	150	100	200	3000	3	3 A	10	−700	〃				50 *			410	ダーリントン
〃 1793	〃	〃	〃	100	100	10A	50W (Tc=25°C)	150	100	100	8000	3	5 A	10	−1A	〃				50 *			410	ダーリントン
〃 1794	〃	〃	〃	200	200	10A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	4000	3	5 A	10	−1A	〃				50 *			410	ダーリントン
〃 1795	〃	〃	Si. T	500	400	10A	50W (Tc=25°C)	150	100	500	450	2	7 A	10	−1A	t_{on}< 2 μs, t_f<15μs t_{stg}<15μs				10 *			410	ダーリントン
〃 1796	サンケン	PA	Si. TP	60±10	60±10	4 A	20W (Tc=25°C)	150	10	50	5000	4	3 A										400	ダンパ内蔵ダーリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考	
2SD1797	富士電機	AF. PA	Si. TP	60	60	7 A	30W (Tc=25°C)	150	100	60	4000	1.5	3 A			t_{on}<1.5μs, t_f<2μs t_{stg}<10μs							402	ダーリントン	
〃 1798	日立	PA	Si. T	300	300	300	15W (Tc=25°C)	150	10	300	5000	1.5	100										268	〃	
〃 1799	三洋	AF. PA	Si. EP	30	25	3 A	15W (Tc=25°C)	150	1	20	15000	2	500	10	−50					120*			411	〃	
〃 1800	〃	〃	〃	80	50	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	0.1	40	15000	2	500	10	−50					120*			411	〃	
〃 1801	〃	SW	〃	60	50	2 A	15W (Tc=25°C)	150	0.1	50	200	2	100	10	−50	t_r<180ns, t_f<90ns t_{stg}<1650ns				150*	12		411	2SB1201とコンプリ	
〃 1802	〃	〃	〃	60	50	3 A	15W (Tc=25°C)	150	1	40	200	2	100	10	−50	t_r<210ns, t_f<105ns t_{stg}<1950ns				150*	25		411	2SB1202とコンプリ	
〃 1803	〃	〃	〃	60	50	5 A	20W (Tc=25°C)	150	1	40	200	2	500	5	−1A	t_r<150ns, t_f<60ns t_{stg}<1500ns				180*	40		411	2SB1803とコンプリ	
〃 1804	〃	〃	〃	60	50	2 A	20W (Tc=25°C)	150	1	40	200	2	500	5	−1A	〃				180*	65		411	2SB1804とコンプリ	
〃 1805	〃	〃	〃	60	20	5 A	15W (Tc=25°C)	150	0.1	50	200	2	500	10	−50	t_r<90ns, t_f<120ns t_{stg}<900ns				120*	45		411		
〃 1806	〃	AF. PA	〃	40	30	2 A	15W (Tc=25°C)	150	1	20	120	0.5	500	2	−500					150*	40		411	ダンパ内蔵	
〃 1807	松下	AF	〃	30	25	100	300	125	1	10	250	10	2										376		
〃 1808	〃	〃	〃	30	25	500	300	125	0.1	25	9000	10	500										376	ダーリントン	
〃 1809	ローム	AF. PA	〃	60	60	1.5A	900	150	1	60	20000	3	500										294	〃	
〃 1810	〃	〃	〃	20	10	2 A	500	150	0.5	16	200	3	100	5	−500					80*	30		138	2SB1210とコンプリ	
〃 1811	〃	〃	〃	20	20	2 A	500	150	0.5	16	200	3	100	5	−500					80*	30		336		
〃 1812	〃	〃	〃	160	160	1.5A	900	150	1	120	120	5	100										294	2SB1212とコンプリ	
〃 1813	日立	〃	Si. T	70	50	4 A	25W (Tc=25°C)	150	1	50	100	4	1 A										391		
〃 1814	〃	〃	〃	120	120	10A	30W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	5 A										391	ダンパ内蔵ダーリントン	
〃 1815	三洋	SW	Si. EP	120	100	3 A	20W (Tc=25°C)	150	1	100	200	5	500			t_{on}<0.3μs, t_f<0.15μs t_{stg}<2.7μs							411		
〃 1816	〃	〃	〃	120	100	4 A	20W (Tc=25°C)	150	1	100	200	5	500			〃							411		
〃 1817	〃	AF	〃	80	60	3 A	15W (Tc=25°C)	150	10	60	5000	2	1 A										411	ダンパ内蔵ダーリントン	
〃 1818	日電	AF. PA	Si. E	60	60	3 A	10W (Tc=25°C)	150	10	60	250	2	600	5	−1.5A					120*	30		225	2SB1217とコンプリ	
〃 1819	松下	AF	Si. EP	30	25	100	150	150	0.1	20	200	10	2							150*	3.5		412	2SB1218とコンプリ	○
〃 1820	〃	〃	〃	30	25	500	150	150	0.1	20	170	10	150							200*	6		412	2SB1219とコンプリ	○
〃 1821	〃	〃	〃	150	150	50	150	150	1	100	200	5	10							150*	2.3		412	2SB1220とコンプリ	○
〃 1822	〃	〃	〃	25	20	500	150	150	0.1	25	400	2	500							200*	10		412		
〃 1823	〃	〃	〃	50	40	50	150	150	0.1	20	1000	10	2							200*	3		412		
〃 1824	〃	〃	〃	100	100	20	150	150	0.1	20	1000	10	2							140*			412		
〃 1825	三洋	AF. PA	〃	70	60	4 A	20W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	2 A	5	−2A					20*			388	ダンパ内蔵ダーリントン	
〃 1826	〃	〃	〃	70	60	7 A	25W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	3.5A	5	−3.5A					20*			388	〃	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1827	三洋	AF. PA	Si. EP	70	60	10A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	5000	2	5 A	5	−5A					20 *			388	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1828	〃	〃	〃	110	100	3 A	20W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	1.5A	5	−1.5A					20 *			388	〃
〃 1829	〃	〃	〃	110	100	5 A	25W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	2.5A	5	−2.5A					20 *			388	〃
〃 1830	〃	〃	〃	110	100	8 A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	4 A	5	−4A					20 *			388	〃
〃 1831	松下	〃	〃	100	60	10A	70W (Tc=25°C)	150	100	100	1000	4	1 A										82	
〃 1832	ローム	〃	Si. TP	80	60	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	80	120	5	1 A	5	−500					8 *	130		405	
〃 1833	〃	〃	〃	100	80	7 A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	120	5	1 A	5	−500					5 *	150		405	
〃 1834	〃	〃	Si. EP	60	60	1 A	500	150	1	60	20000	3	500										336	ダーリントン
〃 1835	三洋	SW	〃	60	50	2 A	750	150	0.1	50	200	2	100	10	−50	t_{on}<35ns, t_f<30ns t_{stg}<550ns				150 *	12		138	2SB1229とコンプリ
〃 1836	〃	〃	〃	50	50	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	100	40	4000	3	800			t_{on}<1.5μs, t_f<4.5μs t_{stg}<12μs							388	〃
〃 1837	〃	〃	〃	50	50	3 A	20W (Tc=25°C)	150	100	40	4000	3	1.5A	5	−1.5A	〃				20 *			388	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1838	〃	〃	〃	50	50	5 A	25W (Tc=25°C)	150	100	40	4000	3	2.5A	5	−2.5A	t_{on}<1.8μs, t_f<4.5μs t_{stg}<12μs				20 *			388	〃
〃 1839	松下	PA	Si. TP	365±30	365±30	5 A	80W (Tc=25°C)	150	100	300	2000	5	5 A										82	〃
〃 1840	三洋	〃	Si. EP	110	100	15A	100W (Tc=25°C)	150	100	100	80	2	1.5A										346	
〃 1841	〃	〃	〃	110	100	25A	120W (Tc=25°C)	150	100	100	80	2	2.5A										346	
〃 1842	〃	〃	〃	110	100	40A	150W (Tc=25°C)	150	100	100	80	2	4 A										346	
〃 1843	日電	〃	〃	60±10	60±10	±1A	1 W	150	0.5	40	10000	2	1 A										278	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1844	松下	SW	Si. TP	1500	700	1.5A	60W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	500			t_f<0.8μs							82	ダンパ内蔵
〃 1845	〃	〃	〃	1500	700	2.5A	60W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	500			〃							82	〃
〃 1846	〃	〃	〃	1500	700	3 A	60W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	500			〃							82	〃
〃 1847	〃	〃	〃	1500	700	5 A	100W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	1 A			〃							82	〃
〃 1848	〃	〃	〃	1500	700	6 A	100W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	1 A			〃							82	〃
〃 1849	〃	〃	〃	1500	700	7 A	120W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	1 A			〃							82	
〃 1850	〃	〃	〃	1500	700	7 A	120W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	1 A			〃							82	
〃 1851	三洋	AF	Si. EP	80	50	200	200	150	0.1	60	20000	2	10										176	ダーリントン
〃 1852	〃	〃	〃	80	50	200	300	150	0.1	60	20000	2	10										92	〃
〃 1853	〃	〃	〃	80	60	1.5A	700	150	10	60	6000	2	1 A										138	〃
〃 1854	〃	〃	〃	80	60	1.5A	1 W	150	10	60	6000	2	1 A										294	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 1855	ローム	AF. PA	Si. TP	80	60	4 A	30W (Tc=25°C)	150	10	60	120	5	1 A	5	−500					8 *	90		405	
〃 1856	〃	〃	Si. EP	50	50	5 A	25W (Tc=25°C)	150	10	40	5000	3	2 A								25		405	ダンパ内蔵ダーリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1857	ローム	AF. PA	Si. EP	120	120	1.5A	1 W	135	1	100	180	5	100	5	−100					80 *	20		415	
〃 1858	〃	AF	〃	40	32	1 A	1 W	135	0.5	20	180	3	100										415	
〃 1859	〃	〃	〃	80	80	700	1 W	135	0.5	50	180	3	100										415	
〃 1860	〃	〃	〃	50	50	500	600	125	0.5	30	180	3	100										415	
〃 1861	〃	AF. PA	〃	40	40R	2 A	1 W	135	1	24	20000	3	500	6	−100					150 *	11		415	ダーリントン
〃 1862	〃	AF	〃	40	32	2 A	1 W	135	1	20	180	3	500	5	−500					100 *	50		415	
〃 1863	〃	〃	〃	100	80	1 A	1 W	135	1	80	180	3	100	10	−50					100 *	20		415	
〃 1864	〃	AF. PA	〃	60	50	3 A	1 W	150	1	40	180	3	500								40		415	
〃 1865	〃	AF	〃	30	15	1 A	600	125	0.5	20	270	3	100										415	
〃 1866	〃	AF. PA	〃	60±10	60±10	1.5A	1 W	135	1	40	10000	2	1 A								25		415	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1867	〃	〃	〃	100	100	1.5A	1 W	150	1	100	10000	2	1 A								25		415	〃
〃 1868	日 立	〃	Si. E	160	160	100	900	150	10	140	140	5	10										251	
〃 1869	〃	〃	〃	200	200	100	900	150	10	160	140	5	10										251	
〃 1870	〃	AF	〃	30	25	1 A	1 W	150	0.2	25	1500	1	500										336	
〃 1871	三 菱	PA	〃	40	20	2 A	10W (Tc=25°C)	150	1	25	110	4	500										416	
〃 1872	〃	〃	〃	60	40	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	1	25	110	4	500										416	
〃 1873	〃	〃	〃	110	100	800	10W (Tc=25°C)	150	10	25	110	4	300										416	
〃 1874	〃	〃	〃	130	120	800	10W (Tc=25°C)	150	10	25	110	4	300										416	
〃 1875	ローム	AF. PA	Si. EP	50	50	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	40	10000	2	1 A										74	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1876	三 洋	SW	Si. TP	1500	800	3 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	500			t_f<0.3μs							397	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 1877	〃	〃	〃	1500	800	4 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 1878	〃	〃	〃	1500	800	5 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 1879	〃	〃	〃	1500	800	6 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 1880	〃	〃	〃	1500	800	8 A	70W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 1881	〃	〃	〃	1500	800	10A	70W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 1882	〃	〃	〃	1500	800	3 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	水平偏向用
〃 1883	〃	〃	〃	1500	800	4 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 1884	〃	〃	〃	1500	800	5 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 1885	〃	〃	〃	1500	800	6 A	60W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃
〃 1886	〃	〃	〃	1500	800	8 A	70W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1 A			〃							397	〃

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$* $h_{ie(real)}$ (Ω)	外形	備考
2SD1887	三洋	SW	Si.TP	1500	800	10A	70W (Tc=25°C)	150	10	800	15	5	1A			t_f<0.3μs							397	水平偏向用
〃 1888	ローム	AF.PA	Si.EP	120	120	6A	40W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	2A										268	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1889	〃	〃	〃	120	120	6A	30W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	2A										405	〃
〃 1890	松下	〃	Si.TP	100	80	3A	35W (Tc=25°C)	150	100	100	15000	5	2A										364	ダーリントン
〃 1891	〃	〃	〃	110	90	4A	40W (Tc=25°C)	150	100	110	15000	5	3A										364	〃
〃 1892	〃	〃	〃	120	110	5A	45W (Tc=25°C)	150	100	120	15000	5	4A										364	〃
〃 1893	〃	〃	〃	150	130	6A	50W (Tc=25°C)	150	100	130	15000	5	5A										82	〃
〃 1894	〃	〃	〃	160	140	7A	70W (Tc=25°C)	150	100	160	15000	5	6A										82	〃
〃 1895	〃	〃	〃	160	140	8A	100W (Tc=25°C)	150	100	160	15000	5	7A										82	〃
〃 1896	ローム	〃	〃	100	100	5A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	120	5	1A	5	−500					8*	100		268	
〃 1897	〃	〃	〃	100	100	5A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	120	5	1A	5	−500					8*	100		405	
〃 1898	〃	〃	Si.EP	100	80	1A	500	150	0.5	50	180	3	500	10	−50					100*	20		336	
〃 1899	日電	〃	Si.E	60	60	3A	10W (Tc=25°C)	150	10	60	200	2	600	5	−1.5A					120*	30		186	
〃 1900	日立	〃	Si.T	60	60	4A	25W (Tc=25°C)	150	100	60	5000	3	2A										391	ダーリントン
〃 1901	〃	〃	〃	60	60	8A	25W (Tc=25°C)	150	100	60	5000	3	4A										391	〃
〃 1902	三洋	〃	Si.TP	60	60	3A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	140	5	500	5	−500					40*	110		418	2SB1266 とコンプリ
〃 1903	〃	〃	Si.EP	60	30	8A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	140	2	1A	5	−1A					120*			418	2SB1267 とコンプリ
〃 1904	〃	〃	〃	60	50	5A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	140	2	1A	5	−1A					30*	100		418	2SB1268 とコンプリ
〃 1905	〃	〃	〃	60	50	7A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	140	2	1A	5	−1A					10*			418	2SB1269 とコンプリ
〃 1906	〃	〃	〃	90	80	5A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	140	2	1A	5	−1A					20*			418	2SB1270 とコンプリ
〃 1907	〃	〃	〃	90	80	6A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	140	2	1A	5	−1A					20*			418	2SB1271 とコンプリ
〃 1908	〃	〃	〃	330	150	7A	50W (Tc=25°C)	150	100	200	40	1	1A			t_f<0.5μs							418	水平偏向用
〃 1909	〃	PA	Si.TP	500	300	6A	45W (Tc=25°C)	150	100	400	500	2	4A										364	ダーリントン
〃 1910	日立	SW	Si.T	1500	600	3A	40W (Tc=25°C)	150	500	1500	10	5	300			t_f<0.8μs							417	ダンパ内蔵 水平偏向用
〃 1911	〃	〃	〃	1500	600	5A	50W (Tc=25°C)	150	500	1500	12	5	1A			t_f< 1μs							417	〃
〃 1912	三洋	PA	Si.EP	60	60	3A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	140	5	500	5	−500					100*	40		268	
〃 1913	〃	〃	〃	60	60	3A	20W (Tc=25°C)	150	100	40	140	5	500	5	−500					100*	40		388	2SB1274 とコンプリ
〃 1914	〃	AF	〃	100	80	2A	10W (Tc=25°C)	150	10	60	15000	3	1A										398	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1915	松下	〃	〃	50	20	300	300	150	10	50	700	2	4										376	
〃 1916	東芝	SW.PA	Si.E	50	50	2A	1W	150	10	40	5000	2	1A			t_{on}<1.2μs, t_f<1.8μs t_{stg}<12μs							387	ダンパ内蔵 ダーリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$* h_{ie}(real) (Ω)	外形	備考
2SD1917	松下	AF	Si. EP	60±10	60±10	1 A	1.2W	150	1	25	20000	10	1 A										222	ダーリントン
〃 1918	ローム	AF. PA	〃	160	160	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	1	120	120	5	100							80 *	20		403	
〃 1919	〃	PA	〃	40	32	2 A	750	135	1	20	270	3	500	5	−500					100 *	50		415	
〃 1920	〃	AF	〃	30	15	1 A	600	125	0.5	20	270	3	100	5	−50					150 *	15		415	
〃 1921	〃	〃	〃	50	50	500	400	125	0.5	30	200	3	100	5	−20					250 *	6.5		415	
〃 1922	日立	PA	Si. E	25	25	800	900	150	0.2	20	600	2	100										251	ダンパ内蔵
〃 1923	〃	AF. PA	Si. T	80	80	4 A	25W (Tc=25°C)	150	100	80	5000	3	2 A										391	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1924	〃	〃	〃	80	80	8 A	25W (Tc=25°C)	150	100	80	5000	3	4 A										391	〃
〃 1925	〃	〃	〃	120	120	3 A	25W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	1.5A										391	〃
〃 1926	〃	〃	〃	200	200	10A	30W (Tc=25°C)	150	100	200	5000	3	5 A										391	ダーリントン
〃 1927	〃	〃	〃	120	120	6 A	25W (Tc=25°C)	150	100	120	5000	3	3 A										391	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1928	日電	SW	Si. E	100	100	5 A	20W (Tc=25°C)	150	10	100	8000	2	2 A			t_{on} < 3 μs, t_f < 3 μs t_{stg} < 5 μs							96	
〃 1929	ローム	AF. PA	Si. EP	60±10	60±10	2 A	1.2W	150	10	40	5000	2	1 A								25		294	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1930	〃	〃	〃	100	100	2 A	1.2W	150	10	100	5000	2	1 A								25		294	ダーリントン
〃 1931	〃	〃	〃	60±10	60±10	2 A	1.2W	150	10	40	10000	2	1 A								25		294	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1932	〃	〃	〃	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	3000	3	2 A										268	〃
〃 1933	〃	〃	〃	80	80	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	3000	3	2 A										405	〃
〃 1934	松下	PA	〃	40	20	5 A	1 W	150	0.1	10	300	2	500										413	
〃 1935	三洋	AF. PA	〃	15	15	800	200	150	0.1	12	250	2	50	2	−50					300 *	15		176	2SB1295 とコンプリ
〃 1936	〃	〃	〃	15	15	800	300	150	0.1	12	250	2	50	2	−50					200 *	10		92	2SB1296 とコンプリ
〃 1937	松下	AF	〃	120	120	500	1 W	150	10	120	160	10	150										413	
〃 1938	〃	〃	〃	50	20	300	200	150	10	50	1000	2	4										176	
〃 1939	日電	PA	〃	150	60	±1.5A	750	150	0.5	100	6000	2	1 A										278	
〃 1940	三洋	AF. PA	〃	100	85	6 A	25W (Tc=25°C)	150	100	40	100	5	1 A	5	−1A					15 *	110		388	
〃 1941	日立	SW	Si. T	1500	650	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	1200	15	5	300			t_f < 1 μs							417	水平偏向用
〃 1942	ローム	AF	Si. EP	40	32	2 A	1.2W	150	0.5	20	180	3	500										294	
〃 1943	〃	AF. PA	Si. TP	80	60	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	800	4	500	5	−200					50 *	60		268	
〃 1944	〃	〃	〃	80	60	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	800	4	500	5	−200					50 *	60		405	
〃 1945	日立	〃	Si. T	1000	1000	500	20W (Tc=25°C)	150	5	800	20	5	10										377	
〃 1946	〃	〃	Si. E	15	10	1 A	1 W (Tc=25°C)	150	0.1	12	800	0.3	500										336	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE} V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1947	東芝	AF. PA. SW	Si. E	100	100	10A	30W (Tc=25°C)	150	10	100	800	1	1 A			t_{on}< 3 μs, t_f<4.5μs t_{stg}< 9 μs							381	
〃 1948	〃	〃	〃	50	50	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	45	800	1	1 A			〃							381	
〃 1949	ローム	AF	Si. EP	50	50	500	200	125	0.5	30	180	3	100	5	−20					250*	5		412	
〃 1950	日電	AF. RF	Si. E	30	25	2 A	400	150	0.1	30	1500	2	1 A										336	
〃 1951	〃	AF. PA	〃	20	16	3 A	750	150	0.1	20	300	2	100										138	
〃 1952	〃	〃	〃	20	16	3 A	400	150	0.1	20	300	2	100										336	
〃 1953	三洋	〃	Si. EP	120	120	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	100	8000	3	1 A										296	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1954																								
〃 1955	三洋	AF. PA	Si. EP	110	100	3 A	20W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	1.5A										411	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1956	ローム	〃	Si. TP	120	120	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	120	300	5	1 A										268	ダンパ内蔵
〃 1957	〃	〃	〃	120	120	7 A	30W (Tc=25°C)	150	10	120	300	5	1 A										405	〃
〃 1958	三洋	SW	〃	200	60	4.5A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	80	5	1 A			t_f< 1 μs							388	
〃 1959	日立	〃	Si. T	1400	650	10A	50W (Tc=25°C)	150	500	1400	15	5	1 A			〃							417	
〃 1960	ローム	AF	Si. EP	30	20	5 A	750	150	0.5	20	220	3	500										138	
〃 1961	〃	〃	〃	30	20	5 A	1.2W	150	0.5	20	220	3	500										294	
〃 1962	〃	〃	〃	30	20	5 A	300	150	0.5	20	220	3	500										235	
〃 1963	〃	〃	〃	30	20	5 A	500	150	0.5	20	220	3	500										336	
〃 1964	松下	PA	〃	130	80	15A	50W (Tc=25°C)	150	10	100	120	2	3 A										364	
〃 1965	ローム	AF. PA	〃	120	80	1 A	5 W (Tc=25°C)	150	1	100	180	3	500										244	
〃 1966	〃	〃	〃	80	80	700	5 W (Tc=25°C)	150	0.5	50	180	3	100										244	
〃 1967	〃	〃	〃	40	40	2 A	5 W (Tc=25°C)	150	1	24	20000	3	500										244	ダーリントン
〃 1968	〃	〃	〃	40	32	2 A	5 W (Tc=25°C)	150	1	20	180	3	500										244	
〃 1969	〃	〃	〃	50	50	2 A	500	150	0.5	50	180	3	500										366	
〃 1970	日立	PA	Si. T	24	24	2 A	10W (Tc=25°C)	150	1	20	16000	2	2 A										160	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1971	松下	AF. PA	Si. TP	400	400	500	1.2W	150	100	400	70	5	30										222	
〃 1972	三菱	PA	Si. E	60	60	3 A	15W (Tc=25°C)	150	1	50	600	5	500										349	
〃 1973	松下	AF. PA	Si. TP	80	60	2 A	1.2W	150	100	80	1000	4	300										222	
〃 1974	日立	PA	Si. E	25	25	800	1 W	150	0.2	20	600	2	100										336	
〃 1975	松下	AF. PA	Si. TP	170	170	15A	150W (Tc=25°C)	150	50	170	130	5	1 A										393	
〃 1976	日立	AF. PA	Si. T	300	300	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	300	2000	2	4 A										268	ダンパ内蔵 ダーリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1977	日電	AF. PA	Si. TP	120	120	8 A	65W (Tc=25°C)	150	50	120	140	5	1 A										404	
〃 1978	日立	〃	Si. E	120	120	1.5A	900	150	10	100	10000	3	1 A										251	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1979	松下	AF	Si. EP	50	20	300	150	150	1	50	1500	2	4							150 *			412	
〃 1980	ローム	AF. PA	〃	100	100	2 A	10W (Tc=25°C)	150	10	100	3000	2	1 A								25		403	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1981	三洋	AF	〃	100	80	2 A	1 W	150	10	60	7000	3	1 A										294	〃
〃 1982	日立	AF. PA	Si. T	300	300	6 A	80W (Tc=25°C)	150	10	240	2000	2	4 A										373	〃
〃 1983	ローム	〃	Si. EP	60±10	60±10	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	10	40	10000	2	1 A										405	〃
〃 1984	日立	AF	Si. E	30	25	1 A	900	150	0.2	25	1500	1	500										251	
〃 1985	松下	PA	Si. TP	60	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	I_{CE} 200	V_{CE} 60	120	4	1 A										364	
〃 1986	ローム	AF. PA	Si. EP	60	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	100	60	5000	3	2 A										268	ダーリントン
〃 1987	〃	〃	〃	60	60	4 A	30W (Tc=25°C)	150	100	60	5000	3	2 A										405	〃
〃 1988	〃	〃	〃	45±5	45±5	2 A	25W (Tc=25°C)	150	10	30	3000	2	1 A										268	ダンパ内蔵 ダーリントン
〃 1989	〃	〃	〃	45±5	45±5	2 A	20W (Tc=25°C)	150	10	30	3000	2	1 A										405	〃
〃 1990	松下	〃	Si. T	80	60	4 A	35W (Tc=25°C)	150	100	80	200	4	1 A										268	
〃 1991	〃	AF	Si. EP	30	25	100	400	150	1	20	300	10	2										259	
〃 1992	〃	〃	〃	30	25	500	600	150	0.1	20	170	10	10										259	
〃 1993	〃	〃	〃	35	35	100	400	150	0.1	20	460	10	2										259	
〃 1994	〃	PA	〃	30	25	1 A	600	150	0.1	20	170	10	500										259	
〃 1995	〃	〃	〃	50	40	50	400	150	0.1	20	1000	10	2										259	
〃 1996	〃	〃	〃	25	20	500	600	150	0.1	25	500	2	500										259	
〃 1997	三洋	AF	〃	40	30	3 A	1.5W	150	1	30	180	2	500	バイアス抵抗内蔵形 (R_B=160±48Ω, R_{BE}=800±240Ω)									336	ダンパ内蔵
〃 1998	〃	〃	〃	40	30	3 A	1.5W	150	1	30	150	2	500	バイアス抵抗内蔵形 (R_B= 0, R_{BE}=800±240Ω)									336	〃
〃 1999	〃	〃	〃	30	20	4 A	1.5W	150	1	20	180	2	500	バイアス抵抗内蔵形 (R_B= 0, R_{BE}=1.5k±0.45kΩ)									336	〃
〃 2000	松下	AF. PA	Si. T	80	60	4 A	35W (Tc=25°C)	150	100	80	200	4	1 A										364	
〃 2001	〃	SW	Si. TP	1500	700	1.5A	40W (Tc=25°C)	150	10	750	10	5	500			t_f<0.8μs							268	ダンパ内蔵
〃 2002	三洋	〃	〃	1500	800	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	800	16	5	1 A			t_{on}< 4 μs, t_f<0.4μs t_{stg}< 4 μs							397	
〃 2003																								
〃 2004																								
〃 2005																								
〃 2006																								

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルスh_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SD2007																								
〃 2008																								
〃 2009																								
〃 2010																								
〃 2011																								
〃 2012	東芝	PA	Si. T	60	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	100	60	180	5	500										299	
〃 2013																								
〃 2014	サンケン	PA	Si. T	80	80	4 A	25W (Tc=25°C)	150	10	80	5000	2	3 A										400	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 2015	〃	〃	〃	120	120	4 A	25W (Tc=25°C)	150	10	120	5000	2	2 A										400	〃
〃 2016	〃	〃	〃	200	200	3 A	25W (Tc=25°C)	150	10	200	5000	2	1 A										400	〃
〃 2017	〃	〃	Si. TP	300	250	6 A	35W (Tc=25°C)	150	100	300	4000	2	2 A										400	ダーリントン
〃 2018	松下	〃	Si. EP	60±10	60±10	1 A	1.2W	150	1	25	20000	10	1 A										222	〃
〃 2019	日立	AF	Si. E	150	80	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	5	120	10000	2	1 A										160	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 2020	ローム	AF. PA	Si. TP	150	150	2 A	40W (Tc=25°C)	150	10	150	180	5	1 A										268	
〃 2021	〃	〃	〃	150	150	2 A	30W (Tc=25°C)	150	10	150	180	5	1 A										405	
〃 2022	〃	〃	〃	60±10	60±10	2 A	25W (Tc=25°C)	150	10	40	3000	2	1 A										268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 2023	〃	〃	〃	80	60	3 A	40W (Tc=25°C)	150	10	60	180	5	1 A	5	−500					8 *	70		268	2SB1033とコンプリ
〃 2024	〃	〃	Si. EP	120	120	8 A	40W (Tc=25°C)	150	10	120	10000	3	2 A										268	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 2025	〃	〃	〃	120	120	8 A	30W (Tc=25°C)	150	10	120	10000	3	2 A										405	〃
〃 2026	〃	〃	〃	30	30	300	200	150	0.1	30	30000	5	100	5	−10					200 *			176	ダーリントン
〃 2027	三洋	〃	Si. TP	60	60	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	40	150	5	500										268	
〃 2028	〃	AF	Si. EP	8	8	700	200	150	0.1	6	300	2	50										176	E−B間にZD接続
〃 2029	松下	AF. PA	Si. TP	160	160	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	160	130	5	1 A										393	
〃 2030	日立	AF	Si. E	160	160	100	400	150	10	140	120	5	10										138	
〃 2031	〃	〃	〃	200	200	100	400	150	10	140	120	5	10										138	
〃 2032	ローム	AF. PA	Si. EP	80	80	4 A	20W (Tc=25°C)	150	100	80	3000	3	2 A										165	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 2033	〃	〃	〃	120	120	1.5A	15W (Tc=25°C)	150	1	100	120	5	100										165	
〃 2034	〃	〃	Si. TP	80	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	10	60	120	5	500										165	
〃 2035	〃	〃	〃	80	60	4 A	25W (Tc=25°C)	150	10	60	120	5	1 A										165	
〃 2036	〃	〃	〃	100	80	7 A	25W (Tc=25°C)	150	10	100	120	5	1 A										165	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SD2037	ローム	AF. PA	Si. EP	60	50	3 A	20W (Tc=25°C)	150	1	40	120	3	500								40		165	
〃 2038	〃	〃	Si. TP	80	60	5 A	25W (Tc=25°C)	150	10	80	120	5	1 A										165	
〃 2039	〃	〃	Si. EP	100	100	2 A	15W (Tc=25°C)	150	10	100	4000	2	1 A										165	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 2040	〃	〃	Si. TP	100	100	5 A	25W (Tc=25°C)	150	10	100	120	5	1 A										165	
〃 2041	〃	〃	Si. EP	60±10	60±10	2 A	15W (Tc=25°C)	150	10	40	4000	2	1 A										165	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 2042	〃	〃	〃	60±10	60±10	5 A	20W (Tc=25°C)	150	10	40	10000	3	2 A										165	〃
〃 2043	〃	〃	〃	120	120	6 A	25W (Tc=25°C)	150	100	120	10000	3	2 A										165	〃
〃 2044	〃	〃	Si. TP	80	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	100	80	1000	4	500										165	
〃 2045	サンケン	PA	〃	120	120	6 A	50W (Tc=25°C)	150	10	120	6000	2	3 A										172	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 2046	日立	AF. PA	Si. E	50	50	1.5A	1 W	150	100	40	5000	3	1 A										251	〃
〃 2047	富士電機	SW	Si. TP	1500	1500S	5 A	80W (Tc=25°C)	150	50	750	25	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 3 μs							202	
〃 2048	三洋	AF. PA	Si. EP	110	100	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	1.5A										418	ダンパ内蔵ダーリントン
〃 2049	〃	〃	〃	110	100	5 A	35W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	2.5A										418	〃
〃 2050	〃	〃	〃	110	100	8 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	4000	3	4 A										418	〃
〃 2051	松下	PA	Si. E	60±10	60±10	1.5A	12W (Tc=25°C)	150	1	45	20000	10	1 A										364	〃
〃 2052	〃	AF. PA	Si. T	150	150	9 A	100W (Tc=25°C)	150	50	150	120	5	1 A										82	
〃 2053	〃	〃	Si. TP	150	150	9 A	100W (Tc=25°C)	150	50	150	130	5	1 A										365	
〃 2054	日立	AF	Si. E	100	50	1 A	500	150	0.1	80	240	2	100										336	
〃 2055	ローム	AF. PA	Si. TP	80	60	10A	40W (Tc=25°C)	150	10	80	100	5	1 A										268	
〃 2056	〃	〃	〃	80	60	10A	30W (Tc=25°C)	150	10	80	100	5	1 A										405	
〃 2057	松下	SW	〃	1500	700	5 A	100W (Tc=25°C)	150	10	750	8	10	5 A			t_f<0.8μs							155	ダンパ内蔵
〃 2058	韓国電子	PA. SW	Si. T	60	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	100	60	60~300	5	500	5	−500	t_{on}<0.8μs, t_f<0.8μs t_{stg}<1.5μs				3 *	70		381	
〃 2059	〃	PA	〃	100	100	5 A	30W (Tc=25°C)	150	100	100	40~240	5	1 A	5	−1A					12 *	100		381	
〃 2060	〃	〃	〃	80	80	4 A	25W (Tc=25°C)	150	30	80	40~240	5	500	5	−500					8 *	90		381	
〃 2061	ローム	AF. PA	Si. TP	80	60	3 A	30W (Tc=25°C)	150	10	60	60~500	5	500	5	−500					8 *	70		381	
〃 2062	〃	〃	〃	100	80	7 A	80W (Tc=25°C)	150	10	100	180	5	1 A										334	
〃 2063	日立	AF	Si. E	15	10	1 A	900	150	0.1	12	700	0.3	500										251	
〃 2064	松下	AF. PA	Si. TP	120	120	6 A	70W (Tc=25°C)	150	50	120	120	5	1 A										82	
〃 2065	〃	〃	Si. T	140	140	7 A	80W (Tc=25°C)	150	50	140	120	5	1 A										82	
〃 2066	〃	〃	〃	160	160	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	160	120	5	1 A										365	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD2067	松下	AF. PA	Si. EP	120	100	2 A	1 W (Tc=25°C)	150	0.1	25	18000	10	1 A										259	
〃 2068	〃	〃	〃	60±10	60±10	1 A	1 W (Tc=25°C)	150	1	25	18000	10	1 A										413	
〃 2069																								
〃 2070	松下	AF	Si. EP	60	50	100	400	150	1	20	310	10	2										259	
〃 2071	〃	PA	〃	30	25	500	600	150	0.1	20	160	10	10										259	
〃 2072	〃	AF	〃	55	55	100	400	150	0.1	20	400	10	2										259	
〃 2073	〃	〃	〃	50	40	50	400	150	0.1	20	1000	10	2										259	
〃 2074	〃	〃	〃	25	20	500	600	150	0.1	25	500	2	500										259	
〃 2075																								
〃 2076																								
〃 2077																								
〃 2078																								
〃 2079																								
〃 2080																								
〃 2081																								
〃 2082																								
〃 2083																								
〃 2084																								
〃 2085																								
〃 2086																								
〃 2087																								
〃 2088																								
〃 2089																								
〃 2090																								
〃 2091																								
〃 2092																								
〃 2093																								
〃 2094																								
〃 2095																								
〃 2096																								

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
	2SA119	富士通	RF. PA	Si. EP	−40		−300	650	175	−0.1	−10				−10	10	60				200*	4.5	50*	84B	
	〃 120	〃	〃	〃	−25		−300	650	175	−1	−10				−10	10	60				200*	4.5	50*	84B	
★	〃 142A	三菱	RF	Ge. A	−40	−40S	−15	80	85	−5	−12				−6	1	70				8	11	60	12A	
★	〃 217	日立	SW	〃	−25		−100	120	85	−1	−12	30~120	−0.3	−100							14	20	200*	50C	
★	〃 431A	東芝	RF	Ge. Me	−20		−5	70	85	−10	−12				−6	1	−0.95*	PG=16dB (f=200MHz)						50C	
★	〃 432A	〃	〃	〃	−20		−5	70	85	−10	−12				−6	1	−0.95*	PG=14dB (f=200MHz)						50C	
★	〃 440A	三洋	RF. Conv. Mix. Osc	〃	−20		−5	60	85	−30	−2				−6	2	50	PG=14dB (f=100MHz)			350*	1.5	70*	48C	
★	〃 549A	日立	SW	Si. EP	−110		−100	200	175	−1	−20	30~200	−1	−10							100*			182C	
	〃 559A	富士通	SW	〃	−40	−35	−200	350	175	−0.5	−10	50	−1	−10			t_r<30μs, t_f<50μs t_{stg}<250μs							49C	
★	〃 628A	三菱	RF.AF.SW	〃	−60	−60	−100	200	125	−0.1	−25	200	−6	−1	−6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 100ps	138B	2SC1008Aとコンプリ
★	〃 636A	日電	PA. SW	Si. E	−70	−60	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−45	100	−5	−500	−5	100					45*	60		167	2SC1098Aとコンプリ
★	〃 653A	〃	PA	〃	−150	−140	−1A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−120	100	−5	−300	−5	100					60*			134	2SC1161Aとコンプリ
	〃 656A	東芝	PA. SW	Si. TMe	−130	−110	−7A	50W (Tc=25°C)	150	−100	−130	30~300	−5	−1A	−10	1A	t_{on}=0.5μs, t_f=0.4μs t_{stg}=3μs				5*	150		102	2SC519Aとコンプリ
	〃 657A	〃	〃	〃	−100	−80	−7A	50W (Tc=25°C)	150	−100	−100	30~300	−5	−1A	−10	1A	t_{on}=0.5μs, t_f=0.4μs t_{stg}=3μs				5*	150		102	2SC520Aとコンプリ
	〃 658A	〃	〃	〃	−70	−50	−7A	50W (Tc=25°C)	150	−100	−70	30~300	−5	−1A	−10	1A	t_{on}=0.5μs, t_f=0.4μs t_{stg}=3μs				5*	150		102	2SC521Aとコンプリ
★	〃 666A	松下	RF.AF.LN	Si. EP	−45	−45	−50	150	125	−1	−10	250	−5	−2										138	
	〃 673A	日立	RF. AF	Si. E	−50	−50	−500	400	150	−0.5	−20	60~320	−3	−10										138	2SC1213Aとコンプリ
	〃 699A	松下	PA	〃	−50	−40	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−20	120	−5	−1A	−5	500					150*	70	3.3*	161	2SC1226Aとコンプリ
	〃 708A	日電	RF.AF.SW	〃	−100	−80	−700	800	150	−0.1	−60	130	−2	−50	−10	50					95*	25	25*	84B	
★	〃 713A	〃	〃	Si. E ダーリントン	−40	−30	−300	250	125	−0.1	−20	30,000	−5	−100	−10	10					180*	6	200*	138	
★	〃 728A	三菱	RF. AF	Si. EP	−60	−60	−100	200	125	−0.1	−25	200	−6	−10	−6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 60ps	175	
★	〃 740A	東芝	RF. PA	Si. TMe	−150	−150	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−10	−100	75	−10	−500	−10	500					5*	55	25	268	
	〃 743A	日立	〃	Si. E	−80	−80	−1A	8W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	120	−4	−50	−4	30					120*	30		160	2SC1212Aとコンプリ
	〃 745A	サンケン	PA	Si. TMe	−120	−120	−8A	70W (Tc=25°C)	150	−1mA	−120	60	−4	−3A	−12	500					15*	220	10*	102	2SC1403Aとコンプリ
	〃 747A	〃	〃	〃	−140	−140	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−140	60	−4	−3A	−12	500					15*	255	10*	102	2SC1116Aとコンプリ
★	〃 749A	松下	SW	Si. EP	−130	−130	−50	250	125	−0.1	−50	80	−1	−20	−10	10					>40*	3.5		138	
★	〃 774A	松下	RF. LN	〃	−55		−50	150	175	−0.1	−10	540	−5	−2	−5	2		3500	3	60	120*	5	100	243	
★	〃 775A	日立	PA	Si. T	−140	−140	−700	12.5W (Tc=25°C)	150	−10	−30	90	−4	−50	−4	30					30*	35	25	268	
★	〃 776A	東芝	RF. LN	Si. EP	−55	−50	−50	200	150	−0.1	−30	300	−6	−2	−6	1	285	7300	1	21	180*	3	35	195	
	〃 778A	日立	SW	Si. T	−180	−180R	−50	200	125	−1	−150	100	−3	−15	−3	15					50*	<10		138	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA780A	日立	PA. SW	Si. E	−80	−80	−1A	10W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	125	−4	−50	−4	50	t_{on}=110ns, t_{off}=1 μs t_{stg}=900ns				120*	8		234	2SC1517A とコンプリ
〃 794A	松下	PA	Si. EP	−120	−120	−500	1.2W	150			160	−10	−150	−10	50					120*	20		222	2SC1567A とコンプリ
★ 〃 795A	〃	〃	Si. P	−180	−180	−1A	10W (Tc=25°C)	150			65~330	−10	−150	−10	50					120*	<15		236	2SC1565A とコンプリ
〃 808A	サンケン	〃	Si. EMe	−100	−100	−6A	50W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	60	−4	−3A	−12	500					10*	90	8*	102	2SC1619A とコンプリ
〃 811A	日電	RF. AF	Si. E	−120	−120	−50	150	125	−0.05	−120	500	−3	−0.5	−3	1		9.2k	2.7	33	100*	3	20*	176	
〃 817A	東芝	PA	〃	−80	−80	−400	800	150	−0.1	−50	70~240	−2	−50	−10	10					100*	14		241	2SC1627A とコンプリ
〃 845A	日立	AF. SW	〃	−180	−180R	−50	200	175	−1	−150	80	−3	−15	−10	10	t_{stg}<1 μs				>40*	<10		49C	
〃 847A	三菱	AF.LN.RF	Si. EP	−120	−120	−50	200	125	−0.1	−70	250~800	−6	−1	−6	1	V_{NO}<170mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				150*	2.5		138B	2SC1708A とコンプリ
★ 〃 856A	東芝	RF. LN	〃	−50	−50	−50	150	150	−0.1	−35	450	−6	−1	−6	1	NF=1.3dB (f=100MHz, V_{CE}=−6V, I_E=1mA)				140*	4.5	40	49C	
〃 872A	日立	LN	Si. E	−120	−120	−50	300	150	−0.5	−100	250~800	−12	−2	−12	2	NF<1.5dB (f=1kHz, V_{CE}=−6V, I_C=−50μA)				120*	1.8		138	2SC1775A とコンプリ
〃 893A	〃	RF. AF	〃	−120	−120	−50	300	150	−0.5	−100	250~800	−12	−2	−12	2	NF=2dB (1kHz, 6V, 50μA)				120*	1.8		138	2SC1890A とコンプリ
〃 904A	三菱	AF. RF	Si. EP	−120	−120	−50	200	125	−0.1	−70	250~800	−6	−1	−6	1					150*	2.5		138B	
★ 〃 913A	松下	〃	〃	−180	−180	−1A	15W (Tc=25°C)	150			65~330	−10	−150	−10	50					120*	<15		268	2SA913 とコンプリ
〃 962A	東芝	PA	Si. E	−60	−50	−1.5A	1.5W	150	−1	−50	70~240	−2	−150	−10	100					100*	30		177	2SC2194A とコンプリ
★ 〃 964A	日電	〃	〃	−250	−250	−200	10W (Tc=25°C)	150	−1	−200	180	−10	−10	−10	10					100*	3	16*	167C	
〃 968A	東芝	〃	〃	−180	−180	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−160	70~240	−5	−100	−10	100					100*	30		268	2SC2238A とコンプリ
〃 968B	〃	〃	〃	−200	−200	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−160	70~240	−5	−100	−10	100					100*	30		268	2SC2238B とコンプリ
〃 977A	松下	AF. PA	Si. EP	−220	−220	−50	1W	150	−1	−100	65~450	−5	−10	−10	10					80*			222	
〃 985A	日電	PA	Si. E	−150	−150	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−120	150	−5	−300	−5	200					180*	29		268	2SC2275A とコンプリ
〃 1006A	〃	〃	〃	−200	−200	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−150	120	−5	−150	−10	100					80*	45	10*	268	2SC2336A とコンプリ
〃 1006B	〃	〃	〃	−250	−250	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−150	120	−5	−150	−10	100					80*	45	10*	268	2SC2336B とコンプリ
★ 〃 1007A	〃	PA. SW	〃	−150	−150	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−50	−150	150	−5	−1A	−5	200	t_{on}=0.2μs, t_{off}=1 μs t_{stg}=0.7μs				50*	250		102	2SC2337A とコンプリ
〃 1009A	〃	SW	Si. T	−400	−400	−2A	15W (Tc=25°C)	150	−10	−400	20~200	−5	−100			t_{on}<1 μs, t_f<1 μs t_{stg}<2.5μs							268	
★ 〃 1050A	東芝	PA	Si. E	−140	−140	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−140	55~240	−5	−1A	−10	1A					70*	220	2*	102	2SC2460A とコンプリ
★ 〃 1051A	〃	〃	〃	−160	−160	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−10	−160	55~240	−5	−1A	−10	1A					60*	350	2*	102	2SC2461A とコンプリ
〃 1069A	日電	SW	〃	−80	−80	−5A	30W (Tc=25°C)	150	−10	−80	40~200	−5	−3A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							268	2SC2516A とコンプリ
〃 1072A	富士通	PA	Si. P	−150	−150	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−150	110	−5	−1A	−10	1A					60*	300	1.5*	102	2SC2522A とコンプリ
〃 1096A	松下	RF	Si. EP	−70	−60	−2A	1.2W	150	−1	−20	120	−5	−1A	−5	500					150*	55	110	222	
〃 1107A	日電	PA	Si. E	−150	−150	−10A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−130	150	−5	−1A	−5	200					50*	250	10	340	
★ 〃 1108A	〃	〃	〃	−150	−150	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−130	150	−5	−2A	−5	1A					60*	270	10	340	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SA1133A	松下	PA	Si. EP	−200	−180	−2A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−150	120	−10	−150	−10	200					40 *	70	25	268	2SC2660A とコンプリ
〃 1166A	日電	〃	Si. E	−180	−180	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−50	−160	150	−5	−2A	−5	1 A					60 *	320	10	340	
〃 1180A	富士通	SW	Si. EP	−200	−200	−10A	100W (Tc=25°C)	175	−50	−200	20	−5	−500			t_r<300ns, t_f<200ns t_{stg}<250ns							102	
〃 1220A	日電	PA	Si. E	−160	−160	−1.2A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−120	140	−5	−300	−5	200					175 *	26		225	2SC2285A とコンプリ
〃 1227A	〃	〃	〃	−160	−160	−12A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−140	130	−5	−2A	−5	1 A					60 *	280	10	162	2SC2987A とコンプリ
〃 1282A	三菱	RF. AF. PA	Si. EP	−20	−20	−2A	900	150	−0.2	−16	150~500	−4	−100	−2	10					80 *			6	2SC3242A とコンプリ
〃 1285A	〃	〃	〃	−150	−150	−100	900	150	−0.1	−100	150~500	−10	−10	−10	10					200 *	3		6	2SC3245A とコンプリ
〃 1306A	東芝	PA	Si. E	−180	−180	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−160	70~240	−5	−100	−10	100					100 *	30		381	2SC3298A とコンプリ
〃 1306B	〃	〃	〃	−200	−200	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−160	70~240	−5	−100	−10	100					100 *	30		381	2SC3298B とコンプリ
〃 1376A	日電	AF. PA	〃	−200	−200	−100	750	150	−0.1	−200	200	−10	−10	−10	10	t_{on}=0.16μs, t_{off}=1.5μs				120 *	3.5		138	2SC3478A とコンプリ
〃 1386A	サンケン	PA	Si. EP	−180	−180	−15A	130W (Tc=25°C)	150	−100	−180	80	−4	−5A	−12V	2 A					40 *	500	8	324	2SC3519A とコンプリ
〃 1488A	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	25W (Tc=25°C)	150	−100	−80	100	−4	−1A	−12	200					15 *	90	7	400	
〃 1531A	松下	RF	〃	−55	−55	−50	150	150	−0.1	−10	350	−5	−2	−10	10					200 *	6		412	2SC3929A とコンプリ
〃 1534A	〃	〃	〃	−60	−50	−1A	1 W	150	−0.1	−20	180	−10	−500	−10	50					200 *	20		413	2SC3940A とコンプリ
〃 1535A	〃	PA	〃	−180	−180	−1A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−100	160	−10	−150	−10	50					200 *	50		364	2SC3944A とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SB57A	富士通	SW	Ge. A	−45	−30R	−500	225	85	−15	−45	70	−1	−50	−6	1	0.985*	30*	3*	0.3*	2	t_r<2μs, t_f<2μs	t_{stg}<2μs	84B	
★	〃 67A	日立	AF	〃	−60		150	350 (アルミ放熱板付)	70								50~175							66	
★	〃 126A	松下	SW	〃	−60		−3.5A	40W (T_c=45°C)	90	−200	−14	35	−1	−1A										102	
★	〃 127A	〃	〃	〃	−60		−3.5A	40W (T_c=45°C)	90	−200	−14	75	−1	−1A										102	
★	〃 136A	三菱	PA	〃	−60	−40R	−300	150	85	−10	−25	120	−1.5	−50										12B	
★	〃 207A	新電元	〃	〃	−140	−85S	−20A	80W (T_c=25°C)	85	−5mA	−140	40	−1.5	−15A	−6	2A					f_{ae} 2.5kHz			266	
★	〃 208A	〃	〃	〃	−140	−85S	−30A	80W (T_c=25°C)	85	−5mA	−140	100	−1.5	−15A	−6	2A					f_{ae} 2.5kHz			266	
★	〃 213A	〃	SW	〃	−140	−85S	−20A	80W (T_c=25°C)	85	−5mA	−140	40	−1.5	−15A	−6	2A					f_{ae} 2.5kHz			266	
★	〃 214A	〃	〃	〃	−140	−85S	−30A	80W (T_c=25°C)	85	−5mA	−140	100	−1.5	−15A	−6	2A					f_{ae} 2.5kHz			266	
★	〃 216A	三洋	PA	〃	−90	−80R	−3A	24W (T_c=25°C)	85	−500	−20	80	−1.5	−1A							0.5			102	
★	〃 426A	東芝	〃	〃	−45	−45R	−3A	30W (T_c=25°C)	85	−160	−12	60	−1.5	−1A										102	
★	〃 452A	三菱	〃	〃	−45	−45S	−1A	300	85	−30	−12	150	−1	−150										69	
★	〃 495A	〃	〃	〃	−32	−25	−1A	200	85	−20	−12	110	−1	−150										12A	
	〃 502A	東芝	〃	Si. TMe	−110	−80	−3A	25W (T_c=25°C)	150	−100	−110	80	−5	−500	−10	500	t_{on}=1μs, t_f=1μs t_{stg}=3μs				5*	200		99	2SD877 とコンプリ
	〃 503A	〃	〃	〃	−80	−50	−3A	25W (T_c=25°C)	150	−100	−80	80	−5	−500	−10	500	t_{on}=1μs, t_f=1μs t_{stg}=3μs				5	200		99	
	〃 504A	日電	PA. SW	Si. E	−100	−80	−2A	1 W	175	−1	−80	80	−2	−500										84B	2SD78A とコンプリ
	〃 506A	〃	〃	〃	−150	−150	−5A	60W (T_c=25°C)	175	−2mA	−150	70	−5	−1A										102	
★	〃 512A	松下	PA	Si. EMe	−80	−80	−3A	25W (T_c=25°C)	150	−30	−20	60	−3	−1A	−10	200					f_{ae} 70kHz			268	2SD365A とコンプリ
★	〃 513A	〃	〃	〃	−80	−80	−3A	25W (T_c=25°C)	150	−30	−20	60	−3	−1A										267	2SD366A とコンプリ
★	〃 539A	日電	〃	Si. T	−130	−120	−10A	100W (T_c=25°C)	150	−50	−120	80	−5	−2A	−5	200					17*	430		102	2SD287A とコンプリ
★	〃 539B	〃	〃	〃	−150	−140	−10A	100W (T_c=25°C)	150	−50	−120	80	−5	−2A	−5	200					17*	430		102	2SD287B とコンプリ
★	〃 539C	〃	〃	〃	−160	−150	−10A	100W (T_c=25°C)	150	−50	−120	80	−5	−2A	−5	200					17*	430		102	2SD287C とコンプリ
	〃 546A	〃	〃	〃	−200	−150	−2A	25W (T_c=25°C)	150	−50	−150	90	−10	−400	−10	400					5*			268	2SD401A とコンプリ
	〃 547A	〃	〃	〃	−200	−150	−2A	25W (T_c=25°C)	150	−50	−150	90	−10	−400	−10	400					5*			267	2SD402A とコンプリ
★	〃 566A	日立	〃	〃	−70	−60	−4A	40W (T_c=25°C)	150	−1	−50	60~200	−4	−1A	−4	500					7*			268	2SD476A とコンプリ
	〃 611A	〃	〃	Si. E	−150	−120	−7A	60W (T_c=25°C)	150	−10	−120	120	−5	−1A										102	
	〃 612A	〃	〃	〃	−180	−160	−12A	100W (T_c=25°C)	150	−10	−160	100	−5	−1A										102	
★	〃 616A	日電	PA. SW	〃	−100	−100	−5A	60W (T_c=25°C)	150	−10	−80	80	−5	−1A	−5	100					22*	120		295	2SD586A とコンプリ
★	〃 617A	〃	PA	〃	−120	−120	−6A	70W (T_c=25°C)	150	−50	−120	80	−5	−1A	−5	200					14*	220		295	2SD587A とコンプリ
★	〃 618A	〃	〃	〃	−150	−130	−7A	80W (T_c=25°C)	150	−50	−130	80	−5	−1A	−5	200					14*	340		295	2SD588A とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SB621A	松下	PA	Si. EP	−60	−50	−1A	750	150	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	20		138	
〃 646A	日立	〃	Si. E	−120	−100	−50	900	150	−10	−100	60~200	−5	−10	−5	10					140*	4		251	2SD666A とコンプリ
〃 647A	〃	〃	〃	−120	−100	−1A	900	150	−10	−100	60~200	−5	−150	−5	150					140*	20		251	2SD667A とコンプリ
〃 648A	〃	〃	〃	−180	−160	−50	1 W	150	−10	−160	60~200	−5	−10	−10	10					140*	4.5		160	2SD668A とコンプリ
〃 649A	〃	〃	〃	−180	−160	−1.5A	1 W	150	−10	−160	60~200	−5	−150	−5	150					140*	27		160	2SD669A とコンプリ
★ 〃 653A	〃	〃	Si. T	−120	−100	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	60~200	−5	−1A	−5	1 A	t_f=0.5μs				22*			102	2SD673A とコンプリ
★ 〃 654A	〃	〃	〃	−120	−120	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	60~200	−5	−1A	−5	1 A	t_f=0.5μs				22*			102	2SD674A とコンプリ
★ 〃 655A	〃	〃	〃	−160	−140	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−140	60~200	−5	−1A	−5	1 A	t_f=0.5μs				22*			102	2SD675A とコンプリ
★ 〃 656A	〃	〃	〃	−160	−160	−12A	125W (Tc=25°C)	150	−1mA	−140	60~200	−5	−1A	−5	1 A	t_f=0.5μs				22*			102	2SD676A とコンプリ
★ 〃 668A	松下	〃	〃	−80	−80	−3A	25W (Tc=25°C)	150	−200	−60	2000	−3	−500	−3	1.5A					f_{ae} 100kHz			268	ダーリントン
★ 〃 669A	〃	〃	〃	−90	−90	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−200	−80	3000	−3	−1A	−3	3 A					f_{ae} 100kHz			268	ダーリントン
★ 〃 700A	日立	〃	Si. T	−160	−140	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−120	60~200	−5	−1A	−5	1 A	t_f=0.6μs				20*			332	2SD736A とコンプリ
★ 〃 702A	〃	〃	〃	−160	−160	−12A	125W (Tc=25°C)	150	−1mA	−140	60~200	−5	−1A	−5	1 A	t_f=0.6μs				20*			332	2SD738A とコンプリ
〃 703A	日電	PA. SW	Si. E	−100	−100	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−10	−80	100	−5	−500	−5	100					18*	110		268	2SD743A とコンプリ
★ 〃 705A	〃	PA	Si. T	−150	−150	−10A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−140	80	−5	−2A	−5	200					17*	430		340	2SD745A とコンプリ
〃 705B	〃	〃	〃	−160	−160	−10A	120W (Tc=25°C)	150	−50	−140	80	−5	−2A	−5	200					17*	430		340	2SD745B とコンプリ
★ 〃 706A	〃	〃	〃	−220	−220	−10A	200W (Tc=25°C)	150	−50	−180	80	−5	−2A	−5	200					14*	450		265	2SD746A とコンプリ
〃 709A	松下	AF	Si. EP	−45	−45	−500	200	125	−0.1	−20	90~650	−10	−2	−10	1					80*	2.7		176	2SD601A とコンプリ
〃 710A	〃	〃	〃	−60	−50	−500	200	125	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6		176	2SD602A とコンプリ
〃 716A	日立	PA	Si. E	−140	−140	−50	750	150	−0.5	−100	250~500	−12	−2	−12	5					150*	1.8		251	2SD756A とコンプリ
〃 736A	日電	AF	〃	−80	−80	−300	200	150	−0.1	−80	200	−1	−50	−6	10					100*	13		176	2SD780A とコンプリ
〃 744A	〃	PA. SW	〃	−70	−60	−3A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−45	100	−5	−500	−5	100					45*	60		225	2SD794A とコンプリ
〃 745A	松下	LN	Si. EP	−55	−55	−50	300	135	−0.1	−10	180~700	−5	−2										151	2SD661A とコンプリ
〃 748A	日立	PA	Si. T	−120	−100	−6A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	60~200	−5	−1A	−5	1 A	t_f=0.5μs				22*			332	2SD824A とコンプリ
〃 749A	〃	〃	〃	−120	−120	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	60~200	−5	−1A	−5	1 A	t_f=0.5μs				22*			332	2SD825A とコンプリ
〃 750A	松下	PA. SW	Si. EP	−80	−80	−2A	35W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	1000~10000	−4	−1A			t_{on}=0.2μs, t_{off}= 2 μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 750B	〃	〃	〃	−100	−100	−2A	35W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	1000~10000	−4	−1A			t_{on}=0.2μs, t_{off}= 2 μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
★ 〃 751A	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−200	−80	1000~10000	−3	−3A			t_{on}=0.2μs, t_{off}= 2 μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 751B	〃	〃	〃	−100	−100	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−200	−100	1000~10000	−3	−3A			t_{on}=0.2μs, t_{off}= 2 μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
★ 〃 758A	日電	PA	Si. T	−130	−130	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−50	−120	80	−5	−1A										295	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SB759A	松下	AF	Si. EP	−45	−45	−50	250	125	−1	−10	60~700									80 *	2.7		276	
★ 〃 760A	〃	PA	〃	−80	−80	−1A	30W (Tc=25°C)	150	−200	−80	120	−4	−200										268	2SD855Aとコンプリ
★ 〃 760B	〃	〃	〃	−100	−100	−1A	30W (Tc=25°C)	150	−200	−100	120	−4	−200										268	
〃 761A	〃	〃	〃	−80	−80	−3A	35W (Tc=25°C)	150	−200	−80	100	−4	−1A										268	2SD856Aとコンプリ
★ 〃 761B	〃	〃	〃	−100	−100	−3A	35W (Tc=25°C)	150	−200	−100	100	−4	−1A										268	
〃 762A	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−400	−80	100	−4	−1A										268	2SD857Aとコンプリ
★ 〃 762B	〃	〃	〃	−100	−100	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−400	−100	100	−4	−1A										268	
★ 〃 763A	〃	〃	〃	−80	−80	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−400	−80	120	−4	−1A										365	2SD858Aとコンプリ
★ 〃 763B	〃	〃	〃	−100	−100	−5A	60W (Tc=25°C)	150	−400	−100	120	−4	−1A										365	
〃 766A	〃	〃	〃	−60	−50	−1A	500	125	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200 *	20		336	2SD874Aとコンプリ
★ 〃 773A	日電	〃	Si. T	−120	−120	−6A	70W (Tc=25°C)	150	−50	−100	80	−5	−1A										295	
〃 789A	松下	AF	Si. EP	−120	−120	−500	1 W (プリント基板使用)	150			65~330	−10	−150	−10	50					120 *	<30		336	2SD968Aとコンプリ
〃 793A	〃	〃	〃	−60	−50	−1A	1 W	150	−0.1	−20	60~340	−10	−500	−10	50					200 *	20		151	2SD973Aとコンプリ
★ 〃 812A	〃	PA	〃	−80	−80	−4A	60W (Tc=25°C)	150	−400	−80	100	−4	−1A										365	2SD1032Aとコンプリ
〃 849A	日電	〃	Si. T	−130	−130	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−50	−120	80	−5	−1A	−5	200					14 *	340		162	2SD1110Aとコンプリ
〃 850A	富士電機	〃	Si. EP	−80	−80	−10A	50W (Tc=25°C)	150	−10	−80	120	−5	−2A										268	
〃 871A	松下	SW	Si. P	−50	−40	−10A	40W (Tc=25°C)	150	−50	−50	60~260	−2	−3A	−10	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				100 *	400		268	
〃 872A	〃	SW. PA	〃	−80	−80	−8A	45W	150	−100	−80	1000~10000	−3	−4A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 895A	〃	AF	Si. EP	−60	−50	−1A	1200	150	−0.1	−40	2000~20000	−10	−1A										222	ダーリントン 2SD946Aとコンプリ
〃 896A	〃	SW	Si. P	−50	−40	−10A	35W (Tc=25°C)	150	−50	−50	60~260	−2	−2A	−10	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				150 *	200		268	
〃 925A	〃	〃	〃	−50	−40	−7A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−50	60~260	−2	−2A	−10	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				150 *	140		268	
〃 928A	〃	PA	Si. EP	−200	−180	−2A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−200	60~240	−10	−150										363	2SD1250Aとコンプリ
〃 929A	〃	〃	〃	−80	−80	−3A	35W (Tc=25°C)	150			40~250	−4	−1A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.3μs t_s=1.2μs							363	2SD1252Aとコンプリ
〃 930A	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	40W (Tc=25°C)	150			40~250	−4	−1A			t_{on}=0.2μs, t_f=0.2μs t_s=0.5μs							363	2SD1253Aとコンプリ
〃 935A	〃	SW	〃	−50	−40	−10A	35W (Tc=25°C)	150	−50	−50	60~260	−2	−2A	−10	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				150 *	200		363	
〃 936A	〃	〃	〃	−50	−40	−10A	40W (Tc=25°C)	150	−50	−50	60~260	−2	−3A	−10	500	t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				100 *	400		363	
〃 937A	〃	PA. SW	〃	−80	−80	−2A	35W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	1000~10000	−4	−2A			t_{on}=0.4μs, t_f=0.5μs t_s=1.5μs							363	ダーリントン 2SD1260Aとコンプリ
〃 938A	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−200	−80	1000~10000	−3	−3A			t_{on}=0.3μs, t_f=0.5μs t_s=2.0μs							363	ダーリントン 2SD1261Aとコンプリ
〃 939A	〃	SW	〃	−80	−80	−8A	45W (Tc=25°C)	150	−100	−80	1000~10000	−3	−4A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.0μs t_s=2.0μs							363	ダーリントン 2SD1262Aとコンプリ
〃 940A	〃	PA	〃	−200	−180	−2A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−200	60~240	−10	−150										364	2SD1264Aとコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie} real* (Ω)	外形	備考
2SB941A	松下	PA	Si.EP	−80	−80	−3A	35W (Tc=25°C)	150			40~250	−4	−1A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.3μs t_s=1.2μs							364	2SD1266A とコンプリ
〃 942A	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	40W (Tc=25°C)	150			40~250	−4	−1A										364	2SD1267A とコンプリ
〃 947A	〃	SW	〃	−50	−40	−10A	35W (Tc=25°C)	150	−50	−50	60~260	−2	−2A			t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs							364	
〃 948A	〃	〃	〃	−50	−40	−10A	40W (Tc=25°C)	150	−50	−40	60~260	−2	−3A			t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs							364	2SD1445A とコンプリ
〃 949A	〃	PA.SW	〃	−80	−80	−2A	35W (Tc=25°C)	150	−1mA	−80	1000~10000	−4	−2A			t_{on}=0.4μs, t_f=0.5μs t_s=1.5μs							364	ダーリントン 2SD1275A とコンプリ
〃 950A	〃	〃	〃	−80	−80	−4A	40W (Tc=25°C)	150	−200	−80	1000~10000	−3	−3A			t_{on}=0.3μs, t_f=0.5μs t_s=2.0μs							364	ダーリントン 2SD1276A とコンプリ
〃 951A	〃	SW	〃	−80	−80	−8A	45W (Tc=25°C)	150	−100	−80	1000~10000	−3	−4A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.0μs t_s=2.0μs							364	ダーリントン 2SD1277A とコンプリ
〃 952A	〃	〃	〃	−50	−40	−7A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−50	60~260	−2	−2A			t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				150*	140		363	
〃 953A	〃	〃	〃	−50	−40	−7A	30W (Tc=25°C)	150	−50	−50	60~260	−2	−2A			t_{on}=0.1μs, t_f=0.1μs t_s=0.5μs				150*	140		364	2SD1444A とコンプリ
〃 954A	〃	PA	〃	−80	−80	−1A	30W (Tc=25°C)	150			40~450	−4	−200			t_{on}=0.5μs, t_f=0.3μs t_s=1.2μs							364	
〃 977A	〃	AF	〃	−60	−50	−1A	750	150	−0.1	−25	2000~20000	−10	−1A										138	ダーリントン
〃 1000A	日立	APA	Si.E	−30	−25	−1A	1W ((プリント基板使用)	150	−0.1	−20	85~240	−2	−500	−2	500					200*	38		336	2SD1366A とコンプリ
〃 1085A	ローム	PA	Si.EP	−160	−160	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−120	60~200	−5	−100	−5	−100					50*	30		268	2SD1562A とコンプリ
〃 1115A	日電	AF.PA	Si.E	−80	−60	−1A	2W ((セラミック基板使用)	150	−0.1	−80	340	−2	−100	−2	100					120*	25		336	2SD1615 とコンプリ
〃 1116A	〃	〃	〃	−80	−60	−1A	750	150	−0.1	−60	135~400	−6	−100	−2	100					120*	25		138	2SD1616A とコンプリ
〃 1186A	ローム	PA	Si.EP	−160	−160	−1.5A	20W (Tc=25°C)	150	−1	−120	60~200	−5	−100	−5	−100					50*	30		405	2SD1763A とコンプリ
〃 1218A	松下	AF	〃	−45	−45	−100	150	150	−0.1	−20	260	−10	−2							80*			412	2SD1819A とコンプリ
〃 1219A	〃	〃	〃	−60	−50	−500	150	150	−0.1	−20	170	−10	−150							200*			412	2SD1820A とコンプリ

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC89	日立	SW	Ge. A	25		400	120	85	8	12	20~100	−0.2	20										84A	
★	〃 90	〃	〃	〃	25		400	120	85	8	12	20~120	−0.3	200										84A	
★	〃 91	〃	〃	〃	25		400	120	85	8	12	30~200	−0.3	200										84A	
	〃 97A	日電	RF. SW	Si. E	80	45	1 A	800	175	0.5	45	80	10	50	10	−50	t_{stg}<70ns, t_{on}<30ns, t_{off}<90ns				350*	6	30	123	2SA571とコンプリ
★	〃 101A	東芝	RF	Si. TMe	70	50	5 A	30W (Tc=25°C)	150	1 mA	50				10	−0.5A	30				20*	150	15	101	
	〃 108A	〃	RF. SW	Si. E	90	70	800	800	175	0.5	80	40~240	2	200	10	−10	t_{on}=30ns, t_f=20ns t_{stg}=60ns				150*	9	55	84B	
	〃 109A	〃	〃	〃	70	50	800	800	175	0.5	60	40~240	2	200	10	−10	t_{on}=30ns, t_f=20ns t_{stg}=60ns				150*	9	55	84B	
★	〃 154B	日立	RF	Si. TPa	180	150	100	750	175	10	180	50	10	10	10	−10	60				220*	2.5	70*	84C	
★	〃 154C	〃	〃	〃	200	200	100	750	175	0.1	100	90	10	25	10	−10	60				150*	2.5	15*	84C	
★	〃 168	沖	RF. SW	Si. EP	20		200	250	175	0.1	15	85	1	10	10	−10	110	t_{on}<50ns, t_{off}<60ns t_{stg}<40ns			400*	4	70*	49C	
	〃 169	〃	〃	〃	40		200	250	175	0.1	15	85	1	10	10	−10	110	t_{on}<40ns, t_{off}<44ns t_{stg}<26ns			450*	4	70*	49C	
★	〃 183A	日電	RF. V	Si. E	30	25	30	100	150	0.1	25	75	3	0.5	6	−1	80	3000	0.5	6.5	160*	1.8	45	23	
	〃 198A	富士通	PA	Si. EP	50		500	800	175	1	10				10	−20	40				350*	6	50*	85C	
★	〃 219	〃	RF	Si. P	20		25	200	175	0.02	12				60		60				600*	1.3		50C	
★	〃 268A	日電	RF.PA.SW	Si. E	80	80X	30	150	150	3	50				6	−1	55				150*	1.6	50	23	
★	〃 268B	〃	RF. SW	〃	150	150X	30	150	150	0.1	100	120	1	1	6	−1					75*	2.8	25*	23	
	〃 287A	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	35	15	20	150	150	1	15	80	10	5	10	−5	80				1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 10ps	23	
	〃 288A	〃	〃	〃	35	15	20	150	150	0.2	15	80	10	5	10	−5	80				1100*	0.7	$C_c r_{bb'}$ 10ps	23	
★	〃 317A	日立	SW	Si. EMe	100	50	100	350	175	0.1	20	100	6	10	6	−10	t_{on}<0.08μs, t_f<0.2μs t_{stg}<0.7μs				180*	4.5	75	12A	
★	〃 318A	ソニー	RF. SW	Si. PaMe	50	30	100	300	175	0.2	25	90	3	1	6	−2		h_{fe}=4.5dB (f=100MHz)				3	$C_c r_{bb'}$ 80ps	49C	
★	〃 352A	〃	〃	〃	50	30	100	750	175	0.2	25	70	3	1	6	−2		h_{fe}= 3 dB (f=100MHz)			140*	3	$C_c r_{bb'}$ 80ps	181	
★	〃 353A	〃	〃	〃	100	60	100	750	175	0.2	25	70	3	1	6	−2		〃			140*	3	$C_c r_{bb'}$ 80ps	181	
★	〃 380A	東芝	IF	Si. P	35	30	30	200	125	0.5	18	40~240	12	2	10	−1					250*	2	20	33	
★	〃 385A	〃	OSC	Si. EP	30	15	20	200	125	0.5	15	>20	3	8	10	−8		h_{fe}> 6 dB (f=100MHz)			>600*	<1.5	<35	33	
★	〃 386A	〃	〃	〃	20	15	20	200	125	0.5	15	40	3	8	10	−8		h_{fe}=6.0dB (f=100MHz)				1.2	18	33	
	〃 387A	〃	RF. Conv. Mix. Osc	〃	30	15	50	250	125	0.1	15	>20	3	8	10	−8					1000*	1.2	$C_c r_{bb'}$ <12ps	138	
	〃 388A	〃	RF	〃	30	25	50	300	125	0.1	50	20~200	12.5	12.5	12.5	12.5					>300*	0.8~2.0		138	
★	〃 392A	〃	〃	〃	30	20	20	100	150	0.1	15	40~300	10	2	10	−2					1200*	C_{re} 0.15		50C	
	〃 395A	〃	SW	〃	20	12	500	300	175	0.1	20	70~200	1	10	10	−10	t_{on}<40ns, t_f<30ns t_{stg}<50ns				400*	4		49C	
★	〃 402A	ソニー	RF. Conv. Mix. Osc	Si. E	50		100	180	120	0.2	25	90	3	1	6	−1	110				140*	2.5		38	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC403A	ソニー	RF. Conv. Mix. Osc	Si. E	50		100	180	120	0.2	25	60	3	1	6	−1	75				140*	2.2		38	
★	〃 403B	〃	RF. AF	Si.PaMe	50	25	100	320	120	0.2	25	41~175	3	1	6	−2	h_{fe}= 3 dB (f=100MHz)					2	$C_c r_{bb'}$ 40ps	38	
★	〃 403C	〃	〃	〃	60	60	100	320	120	0.2	25	41~175	3	1	6	−2	h_{fe}= 3 dB (f=100MHz)					2	$C_c r_{bb'}$ 40ps	38	
	〃 410A	新電元	SW	Si. DB	200	200	10A	100W (T_c=25°C)	150	20mA	200	37	5	5 A	10	2 A	t_{on}<1.2μs, t_{off}< 5 μs t_s< 4 μs				f_{ae} 0.4			102	
	〃 434A	〃	〃	〃	200	200	30A	100W (T_c=25°C)	150	20mA	200	28	5	10A	10	2 A		〃			f_{ae} 0.4			266	
	〃 487A	東芝	PA	Si. P	150	150R	1.5A	15W (T_c=25°C)	150	1 mA	30	100	2	200	10	−50					20*	85	5	99	
	〃 515A	〃	PA. SW	Si. T	300	300	150	20W (T_c=25°C)	175	10	300	40~170	10	50	50	−20					100*	6		99	
★	2SC563A	松下	RF	Si. EP	40	40	25	300	175	10	40	>38	10	7	10	−5					550*	C_{re} 0.23		117C	フォワードAGC
★	〃 631A	ソニー	RF.AF.LN	Si. E	25	25	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	−0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350ps	38	2SA704とコンプリ
★	〃 632A	〃	RF. LN	〃	50	50	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	−0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350ps	38	2SA705とコンプリ
★	〃 633A	〃	RF.Conv.Mix Osc. SW	〃	25	25	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	−2	t_r<60ns, t_f<150ns t_{stg}<500ns				140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350ps	38	2SA677とコンプリ
★	〃 634A	〃	〃	〃	50	50	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	−2	t_r<60ns, t_f<150ns t_{stg}<500ns				140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350ps	38	2SA678とコンプリ
★	〃 642A	東芝	PA	Si.TMe	1500	800R	1 A	50W (T_c=25°C)	150	10	500	30~160	15	150	15	−200					2*	55	10	102	水平偏向用
★	〃 643A	〃	〃	〃	1500	1500S	2.5A	50W (T_c=25°C)	150	10	500	>5	15	2 A	15	−100	t_f< 1 μs				3*	95	10	102	水平偏向用
★	〃 680A	日立	〃	Si. T	200	140	2 A	12.5W (T_c=25°C)	150	1	30	180	10	200										153	
	〃 681A	〃	〃	〃	250	80	6 A	50W (T_c=25°C)	150	I_{CBX} 15mA	200						t_f<0.5μs							102	水平偏向用
★	〃 685A	〃	〃	Si. TPa	300	300X	100	6.5W (T_c=70°C)	150			60	10	50										153	
	〃 690A	三菱	PA	Si. EP	60	40	4 A	35W (T_c=25°C)	175	500	30	50	10	100			P_o=25W (f=150MHz, V_{CC}=25V, P_i= 4 W)							113	
★	〃 711A	〃	RF. AF	〃	50	45	100	200	125	0.1	25	250	6	1	6	−1		8500	0.6	40	150*	2.5	$C_c r_{bb'}$ 200ps	138B	
★	〃 756A	ソニー	RF. PA	Si.EMe	100	60	4 A	10W (T_c=25°C)	175	1	50	100	2	100	10	−100					100*	45	$C_c r_{bb'}$ 35ps	181	
	〃 780A	東芝	SW	Si. T	150	150	30	400	125	0.1	150	70~240	3	10	10	−2	t_{on}=0.3μs, t_f=0.4μs t_{stg}= 2 μs				100*	2		138	2SA429とコンプリ
	〃 782A	〃	PA	Si. TP	300	300	1.5A	25W (T_c=25°C)	150	30	300	150	10	100	10	−100					10*	70	25	99	
★	〃 805A	ソニー	PA. SW	Si. EPa	240	150	200	750	175	0.2	100	150	5	3	10	−20	h_{fe}= 8 dB (f=100MHz)					2.4	$C_c r_{bb'}$ 45ps	181	2SA923とコンプリ
★	〃 806A	〃	PA	Si. TMe	700	200	10A	125W (T_c=25°C)	150	5 mA	500	40	3	2 A	10	−500					5.5*	285	5	102	
★	〃 807A	〃	〃	〃	580	200	10	125W (T_c=25°C)	150	5 mA	500	60	3	0.1	10	−500					5.5*	285		102	
★	〃 867A	〃	RF. PA	〃	520		3 A	48W (T_c=25°C)	150	50	50	80	3	100	10	−200					8.5*	90	12	100	
	〃 911A	三菱	PA	Si. EP	40	40R	500	1.7W	175	10	15	50	10	100			P_o=1.4W (f=500MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.3W)							271	
	〃 914A	富士通, 沖 日電, 日立	SW	〃	40	35	300	300	175	0.2	20	70	1	30	h_{FE}>14 (2V, 300mA)		t_{on}<80ns, t_{off}<86ns t_{stg}<65ns							49C	
	〃 915A	〃	〃	〃	30	20	300	300	175	0.2	20	70	1	30	h_{FE} (2V, 200mA)		t_{on}<45ns, t_{off}<42ns t_{stg}<27ns							49C	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC926A	ソニー	RF.AF.SW	Si.DB	210	210	30	320	120	0.2	150	100	3	1	10	−10		4500	0.47	4.8	160*	2.2	$C_c r_{bb'}$ 40ps	38	
	〃 936A	日立	PA	Si.TMe	1000	600	1 A	22W (Tc=25°C)	150	10	500	45	10	100	15	−200					7*	35	25	102	
	〃 973A	三菱	〃	Si.EP	40	40R	700	12W (Tc=25°C)	175	10	15	50	10	100			P_o=4 W (f=500MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=1 W)							126	
	〃 975A	〃	〃	〃	40	40R	1.5A	20W (Tc=25°C)	175	100	15	50	10	100			P_o=8 W (f=500MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=3 W)							126	
	〃 979A	東芝	RF.SW	Si.E	100	70	100	300	175	1	100	40~140	1	10	10	−10	t_{on}=25ns, t_f=30ns t_{stg}=400ns				250*	3		49C	
	〃 980A	〃	〃	〃	90	70	100	400	125	0.1	50	70~140	1	10	10	−10	t_{on}=25ns, t_f=30ns t_{stg}=400ns				250*	3		138	
★	〃 985A	日電	RF.LN	〃	20	15	40	300	200	0.1	10	100	10	15	10	−15	NF=4 dB (10V, −3mA, 2GHz)	PG=9.5dB (2GHz)			3700*	0.6	20*	26	
★	〃 987A	〃	〃	〃	20	15	30	250	200	0.1	10	100	10	10	10	−10	NF=3 dB (10V, −3mA, 2GHz)	PG=11dB (2GHz)			4500*	C_{re} 0.4	20*	26	
	〃 988A	〃	RF	〃	20	15	30	200	200	0.1	10	100	10	10	10	−10	NF<2 dB (10V, −3mA, 500MHz)				3000*	C_{re} 0.5	30*	50C	
	〃 988B	〃	〃	〃	20	15	30	200	200	0.1	10	100	10	10	10	−10	NF<1.5dB (10V, −3mA, 500MHz)				3000*	C_{re} 0.5	30*	50C	
★	〃 999A	東芝	RF.PA.SW	Si.TMe	1500	650R	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	30	15	200	15	−200					4	80	10	102	
★	〃 1005A	〃	PA	〃	1400	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	12	15	4 A	15	−500					3*	150	5	102	
	〃 1008A	日電	RF	Si.E	100	80	700	800	150	0.1	60	140	2	50	10	−50					70*	15	25*	84B	2SA708Aとコンプリ
★	〃 1012A	松下	RF.AF	Si.TP	250	250R	60	2.5W (Tc=25°C)	175	2	12	60	20	40	10	−3	35	300	0.4	2.7	100*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 60ps	84B	
★	〃 1033A	〃	〃	〃	250	200	25	300	175	2	12	>20	10	5										49C	
★	〃 1077A	東芝	PA	Si.EP	65	35	6 A	60W (Tc=25°C)	150	1 mA	30	>10	5	1 A	10	−200	P_o=50W (f=175MHz, V_{CC}=28V, P_i=10W)				150*	<100		141	
★	〃 1098A	日電	PA.SW	Si.E	70	60	3 A	10W (Tc=25°C)	150	1	45	100	5	500	5	−100					60*	40		167	2SA636Aとコンプリ
★	〃 1103A	〃	PA	Si.T	250	250	100	800	150	0.1	150	80	10	10	30	−10					80*	<4.8	30	84B	
	〃 1116A	サンケン	〃	Si.TMe	200	140	10A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	60	4	3 A	12	−500					10*	165	13*	102	2SA747Aとコンプリ
★	〃 1122A	東芝	PA	Si.EP	35	18	4.5A	30W (Tc=25°C)	175	50	15	40	5	1.5A	10	−200					400*	20	5*	135	
★	〃 1151A	三菱	RF.PA	Si.EMe	1000	600	1 A	50W (Tc=25°C)	125	200	500	60	10	150	15	−200					5*	65	25	102	
★	〃 1153A	〃	SW	〃	1400	500	2.5A	50W (Tc=25°C)	125	1 mA	1400	20	10	2.5A			t_r<1.5μs, t_f<3 μs t_{stg}<2 μs							102	
★	〃 1170B	東芝	PA	Si.TMe	1500	500	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	>10	10	1 A	10	−500	t_f<1 μs				3*	95	10	102	水平偏向用
★	〃 1172A	〃	〃	〃	1500	600	5 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	2 A	10	−500	t_f<1 μs				2*	165	10	102	水平偏向用
★	〃 1172B	〃	〃	〃	1500	600	7 A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	2 A	10	−500	t_f<1 μs				3*	160	10	102	水平偏向用
★	〃 1178A	三菱	〃	Si.EP	40	18	5 A	35W (Tc=25°C)	175	2 mA	15	30	10	200			P_o=26W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=7 W)							113	
★	〃 1196A	東芝	〃	〃	45	40	1 A	10W (Tc=25°C)	175	200	15	50	10	200	10	−50	P_o=5 W (f=700MHz, V_{CC}=28V, P_i=1 W)				1000*	<10		135	
★	〃 1197A	〃	〃	〃	45	45R	2 A	20W (Tc=25°C)	175	400	15	55	10	500	10	−100	P_o=12W (f=700MHz, V_{CC}=28V, P_i=3 W)				1000*	<20		135	
★	〃 1206A	三菱	〃	〃	45	45R	1.7A	25W (Tc=25°C)	175	1 mA	30	50	25	50			P_o=10.5W (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_i=4 W)							209	
★	〃 1206B	〃	〃	〃	45	45R	2 A	25W (Tc=25°C)	175	1 mA	40	50	25	50			P_o=12W (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_i=4 W)							209	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ab} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
★	2SC1207A	三菱	PA	Si.EP																				209	
★	〃 1207B	〃	〃	〃	45		4 A	50W (Tc=25°C)	175	2 mA	30						P_o>19W, η>50% (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_i=8 W)							209	
★	〃 1208A	〃	〃	〃	36	18	10A	60W (Tc=25°C)	175	2 mA	15						P_o>39W, η>60% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=15W)							127	
	〃 1212A	日立	〃	Si.E	80	80	1 A	8 W (Tc=25°C)	150	5	50	60~200	4	50	4	−30					160 *	30		160	2SA743A とコンプリ
	〃 1213A	〃	AF	〃	50	50	500	400	150	0.5	20	60~320	3	10										138	2SA673A とコンプリ
	〃 1226A	松下	PA	〃	50	40	2 A	10W (Tc=25°C)	150	1	20	120	5	1 A	5	−500					150 *	50	3.3 *	161	2SA699A とコンプリ
★	〃 1241A	東芝	〃	Si.EP	35	18	2 A	20W (Tc=25°C)	175	500	15	50	5	1 A			P_o=11W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=1 W)							135	
★	〃 1242A	〃	〃	〃	35	18	4.5A	20W (Tc=25°C)	175	100	15	40	5	1.5A			P_o=13W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=1.3W)							135	
	〃 1247A	富士通	AF.PA	〃	50	30	500	500	150	0.5	12	160	2	100							60 *	12	70 *	138	
	〃 1271A	日電	RF	Si.E	20	10	30	250	200	0.05	8	100	8	10	8	−10					6000*	Cre 0.4		190	
	〃 1280A	〃	〃	Si.E ダーリントン	40	30	300	250	125	0.1	20	30,000	2	100	10	−10					180 *	5	220 *	138	
	〃 1318A	松下	PA	Si.EP	80	70	500	400	135	0.1	20	160	10	150	10	−50					120 *	11		138	2SA720A とコンプリ
★	〃 1325A	日電	SW	Si.TMe	1500	600	6 A	80W (Tc=25°C)	150	20	1000	19	15	1 A			t_f<0.8μs t_{stg}<10μs							102	
★	〃 1337A	三菱	PA	Si.EP	35	17	2 A	20W (Tc=25°C)	175	200	15	50	10	100			P_o=8 W, η=60% (f=485MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=1.5W)							126	
★	〃 1338A	〃	〃	〃	35	17	5 A	40W (Tc=25°C)	175	500	15	50	10	100			P_o=16W, η=60% (f=485MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=6 W)							126	
★	〃 1358A	日電	SW	Si.TMe	1400	500	5.5A	50W (Tc=25°C)	150	20	1000	19	15	500			t_r<2.5μs, t_f<1 μs t_{stg}<1.5μs							102	
	〃 1360A	松下	RF	Si.EP	60	45	50	1 W	150	1	20	20~100	10	10	10	−10					>300*			294	
★	〃 1367A	日立	PA	Si.TMe	1000	700	1 A	50W (Tc=25°C)	125	10	500	45	10	200	15	−200					6 *	60	25	102	
	〃 1380A	東芝	RF.LN	Si.E	55	50	100	200	150	0.1	18	200~700	6	2	6	−1					80 *	6		49C	
	〃 1398A	松下	RF.PA	Si.EP	70	70	2 A	15W (Tc=25°C)	150	1	40	>30	5	100	5	−500					150 *			268	
	〃 1403A	サンケン	PA	Si.TMe	180	120	8 A	70W (Tc=25°C)	150	1 mA	180	60	4	3 A	12	−500					10 *	130	7 *	102	2SA745A とコンプリ
★	〃 1409A	日立	〃	〃	200	140	2 A	12.5W (Tc=25°C)	150	1	30	100	10	50	10	−50					20 *	95	20	267	
★	〃 1410A	〃	〃	〃	200	140	2 A	12.5W (Tc=25°C)	150	1	30	100	10	50	10	−50					20 *	95	20	268	
	〃 1413A	〃	SW	Si.T	1500	500	5 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CEX} 1 mA	1500				15	−200	t_f<2.3μs				4 *	175		102	水平偏向用
★	〃 1416A	東芝	RF	Si.EP	55	50	50	200	150	0.1	30	350	6	2	6	−1	NF=1 dB (f=100Hz, V_{CE}=6V, I_E=−0.1mA)				100 *	3	45	195	
★	〃 1448A	〃	RF.PA	Si.TMe	150	150	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	20	100	70~140	10	500	10	−500					7 *	35	25	268	
	〃 1469A	新電元	SW	Si.T	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	2 mA	500	12	5	5 A			t_{on}<2 μs, t_f<2 μs t_{stg}<4 μs				10 *			102	T10M40
	〃 1471A	〃	〃	〃	500	400	30A	200W (Tc=25°C)	155	2 mA	500	15	5	10A			t_{on}<2 μs, t_f<2 μs t_{stg}<4 μs				10 *			266	T30M40
	〃 1473A	松下	AF	Si.TP	300	300	70	750	150	1	120	30~220	10	5	10	−10					>50*	<10		138	
★	〃 1478A	〃	RF.LN	Si.EP	55	55	50	150	175	0.1	10	540	5	2	5	−2		5500	0.4	25	150 *	2.2	70	243	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ / f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC1517A	日立	PA.SW	Si.E	80	80	1 A	10W (Tc=25°C)	150	5	50	60~200	4	50	4	−50	t_{on}=0.25μs, t_{off}=3.5μs t_{stg}=3 μs				150*	30		234	2SA780Aとコンプリ
★ 〃 1553A	東芝	LN	Si.EP	20	20	30	175	175	0.1	10	100	10	5	10	−10	NF=1.2dB(500MHz, 10V, 3mA) G_{pe}=15dB(500MHz, 10V, 10mA)				4500*	0.9	40	50C	
〃 1567A	松下	PA	〃	120	120	500	1.2W	150			160	10	150	10	−150					120*	11		222	2SA794Aとコンプリ
〃 1573A	〃	AF	Si.TP	300	300	70	1 W	150	2	12	30~220	10	5	10	−10					80*	4		294	
〃 1573B	〃	〃	〃	400	400	70	1 W	150	2	12	30~220	10	5	10	−10					80*	4		294	
★ 〃 1605A	三菱	RF.PA	Si.EP	35	17	3.5A	35W (Tc=25°C)	175	500	25	10~180	10	0.1A			P_o=16W (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_{in}=1.4W)							113	
〃 1613A	ローム	AF.SW	Si.TP		85	50	150	125			180~820									140*	2.5		235	
〃 1619A	サンケン	PA	Si.TMe	120	100	6 A	50W (Tc=25°C)	175	1 mA	120	60	4	3 A	12	−500					10*	85	12*	102	2SA808Aとコンプリ
〃 1622A	日電	AF	Si.E	120	120	50	200	150	0.05	120	600	3	1	6	−1		14k	5.8	23	110*	1.6	50	176	
〃 1627A	東芝	AF.PA	〃	80	80	400	800	150	0.1	50	70~240	2	50	10	−10					100*	10		241	2SA817Aとコンプリ
〃 1655A	日電	RF.LN	〃	16	8	30	150	175	0.1	10	100	3	10	6	−20	NF< 3 dB (6 V, 5 mA, 500MHz)				8000*	Cre 0.5	40*	320	
〃 1664A	サンケン	PA	Si.TMe	100	80	6 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	1000	4	1 A	10	−500					20*	75	12	99	
〃 1683A	松下	〃	〃	200	180	500	30W (Tc=25°C)	150	10	200	60~200	10	400										268	
〃 1707A	日立	AF.SW	Si.E	70	50	100	200	175	0.5	20	100~200	1	10	10	−10	t_{on}=80ns, t_{off}=300ns t_{stg}=220ns				>100*	2.6		49C	
〃 1708A	三菱	AF.LN.RF	Si.EP	120	120	50	200	125	0.1	70	250~800	6	1	6	−1	V_{NO}<170mV (10V, 1 mA, R_G=100kΩ, A_r=80dB)				150*	1.8		138B	2SA847Aとコンプリ
〃 1711A	富士通	RF	〃	20	13	30	200	175	0.5	10	80	8	10	8	−10					7.5GHz*		30*	262	
〃 1741A	ローム	AF	〃	50	50	500	400	125	0.5	30	82~390	3	100	5	−20					250*	5		138	
★ 〃 1746A	東芝	RF.LN	〃	50	50	50	150	150	0.1	35	450	6	2	6	−1	NF=1.3dB (f=100Hz, V_{CC}= 6 V, I_C=0.1mA)				140*	2	60	49C	
〃 1775A	日立	RF	Si.E	120	120	50	300	150	0.5	100	400~1200	12	2	12	−2					200*	1.6		138	2SA872Aとコンプリ
〃 1788A	松下	AF.PA	Si.EP	25	25	500	600	135	0.1	25	65~220	2	500	10	−50					150*			138	
〃 1864A	日電	SW	Si.E	300	300	7 A	40W (Tc=25°C)	150	100	250	>20	5	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							134	
〃 1867A	〃	〃	Si.EMe	300	300R	7 A	80W (Tc=25°C)	150	100	250	30	5	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							102	
〃 1871A	〃	〃	Si.T	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	5 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							102	
〃 1890A	日立	AF	Si.E	120	120	50	300	125	0.5	100	250~1200	12	2	12	−2					200*	1.6		138	2SA813Aとコンプリ
★ 〃 1913A	松下	PA	〃	180	180	1 A	15W (Tc=25°C)	150	100	180	65~330	10	150	10	−50					120*	<30		268	2SA913Aとコンプリ
〃 1914A	三菱	AF.RF	Si.EP	120	120	50	200	125	0.1	70	250~800	6	1	6	−1					150*	1.8		138B	
〃 1930A	富士通	RF	〃	16	8	30	150	175	0.1	10	80	3	10	6	−20	NF=2.6dB (500MHz, 6 V, 5 mA)				8000*	0.35	30	284	
〃 1946A	三菱	RF.PA	〃	35	17	7 A	50W (Tc=25°C)	175	2 mA	25	50	10	200			P_o=35W, η=70% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i= 3 W)							272A	
〃 1965A	〃	PA	Si.E	40	17	2 A	15W (Tc=25°C)	175	500	25	50	10	100			P_o=6.5W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=0.6W)							97B	エミッタ・ケース接続
〃 1968A	〃	〃	Si.EP	35	17	5 A	40W (Tc=25°C)	175	500	15	50	10	100			P_o=16W, η=60% (f=470MHz, V_{CC}=13.5V, P_i= 4 W)							272A	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC2103A	東芝	PA	Si.EP	40		6 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	15	10~150	5	3 A			P_o>27W, η>60% (f=175MHz, V_{CC}=12.5V, P_i=4.2W)					80		316	
★ 〃 2122A	〃	SW	Si.TMe	1000	400	10A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CEX} 1 mA	1000	>15	10	2.5A	10	−100	t_f< 1 μs				6 *	125		102	水平偏向用
〃 2126A	新電元	〃	Si.T	200		3 A	30W (Tc=25°C)	150	250	200	42	3	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs				36 *			204	T3M20
〃 2127A	〃	〃	〃	200	200	10A	100W (Tc=25°C)	150	250	200	32	3	10A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs				33 *			102	T10M20
〃 2128A	〃	〃	〃	200	200	30A	200W (Tc=25°C)	150	500	200	22	3	30A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.5μs t_{stg}< 2 μs				23 *			266	T30M20
★ 〃 2139A	東芝	〃	〃	500	400	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	>20	5	5 A			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							102	
〃 2194A	〃	PA	Si.E	50	50	1.5A	1.5W	150	1	50	70~240	2	150	10	−100					100 *	20		177	2SA962A とコンプリ
〃 2224A	日電	〃	Si.EP	250	250	200	10W (Tc=25°C)	150	1	200	180	10	10	10	−10					100 *	2	23 *	167C	
〃 2228A	三洋	RF	Si.TP	200	200	50	900	150	1	200	40~320	10	10	30	−10					>50*	< 4		294	
〃 2230A	東芝	PA	Si.T	200	180	100	800	150	0.1	200	120~400	10	10	10	−10					>50*	< 7		241	
〃 2231A	〃	〃	〃	200	180	200	12W (Tc=25°C)	150	0.1	200	100~320	10	50	10	−50					>50*	<10		178	
〃 2238A	〃	〃	Si.E	180	180	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	1	160	70~240	5	100	10	−100					100 *	25		268	2SA968A とコンプリ
〃 2238B	〃	〃	〃	200	200	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	1	160	70~240	5	100	10	−100					100 *	25		268	2SA968B とコンプリ
〃 2257A	松下	AF	Si.EP	220	220	50	1 W	150	1	160	65~450	5	10	10	−10					80 *			222	
〃 2258A	〃	AF.RF	Si.TP	300	300	70	1 W	150	2	12	>40	20	40	10	−10					100 *	3		222	
〃 2258B	〃	〃	〃	400	400	70	1 W	150	2	12	>40	20	40	10	−10					100 *	3		222	
〃 2275A	日電	PA	Si.E	150	150	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	1	120	150	5	300	5	−200					200 *	19		268	2SA985A とコンプリ
〃 2284A	〃	〃	〃	35	18	2 A	20W (Tc=25°C)	200	750	30	60	10	400			P_o=39.5dBm, η=75% (f=500MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=33dBm)					11		326	
〃 2285A	〃	〃	〃	35	18	4 A	43W (Tc=25°C)	200	1.25mA	30	60	10	800			P_o=17W (f=500MHz, V_{CC}=12.6V, P_i=6.3W)					24		326	
〃 2336A	〃	〃	〃	200	200	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	1	150	120	5	150	10	−100					95 *	30	14 *	268	
〃 2336B	〃	〃	〃	250	250	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	1	150	120	5	150	10	−100					95 *	30	14 *	268	
★ 〃 2337A	〃	PA.SW	〃	150	150	10A	100W (Tc=25°C)	150	50	150	150	5	1 A	5	−200	t_{on}=0.2μs, t_{off}=1.8μs t_{stg}=1.5μs				70 *	150		102	2SA1007A とコンプリ
★ 〃 2361A	松下	PA	Si.EP	100	60	4 A	25W (Tc=25°C)	150	10	20	50~240	3	2.5A	10	−200					70 *			268	
〃 2388A	富士通	SW	Si.TP	500	400	7 A	75W (Tc=25°C)	175	100	500	20	5	2 A			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<3.5μs							102	
〃 2429A	〃	〃	Si.EP	600	450	15A	150W (Tc=25°C)	175	100	500	15	5	10A	10	−2A	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<2.5μs				30 *	240		102	
★ 〃 2460A	東芝	PA	Si.E	140	140	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	140	55~240	5	1 A	10	−1A					90 *	130	2 *	102	2SA1050A とコンプリ
★ 〃 2461A	〃	〃	〃	160	160	15A	150W (Tc=25°C)	150	10	160	55~240	5	1 A	10	−1A					80 *	200	2 *	102	2SA1051A とコンプリ
〃 2496A	日電	〃	〃	35	18	10A	100W (Tc=25°C)	200	2 mA	20	60	10	1 A			P_o=46.2dBm (f=500MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=40dBm)					60		368	
〃 2497A	松下	AF	Si.EP	70	60	1.5A	1.2W	150	1	20	30~220	5	1 A	5	−500					150 *	35		222	2SA1096A とコンプリ
〃 2516A	日電	SW	Si.E	150	80	5 A	30W (Tc=25°C)	150	10	80	40~200	5	3 A			t_{on}<0.5μs, t_f<0.5μs t_{stg}<1.5μs							268	2SA1069A とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC2522A	富士通	PA	Si. P	150	150	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	150	110	5	1 A	10	−1A					80 *	180	1.5 *	102	2SA1072A とコンプリ
〃 2556A	松下	RF	Si. EP	180	50	1 A	1.2W	150	0.1	20	150~350	0.5	1 A	10	−50					200 *			222	
〃 2567A	〃	〃	〃	55	55	50	100	125	0.1	10	350	5	2	5	−20					320 *	3.5	45	293	
〃 2570A	日電	〃	Si. E	25	12	70	600	150	0.1	15	40~200	10	20	10	−20	$\lvert S_{21e}\rvert^2$=10dB (f= 1 GHz)				5000*	Cre 0.7		138C	
〃 2587A	〃	PA	〃	150	150	10A	120W (Tc=25°C)	150	50	130	150	5	1 A	5	−200					70 *	150	15	340	
★ 〃 2588A	〃	〃	Si. T	130	150	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	120	150	5	2 A	5	−1A					60 *	170	15	340	
★ 〃 2657A	松下	SW	Si. TMe	900	500	1.5A	70W (Tc=25°C)	150	100	900	> 8	5	1 A	10	−200	t_{on}<1.2μs, t_f<1.2μs t_{stg}< 3 μs				2.5 *			102	
★ 〃 2658A	〃	〃	〃	900	500	5 A	90W (Tc=25°C)	150	100	900	> 8	5	3 A	10	−500	t_{on}<1.2μs, t_f<1.2μs t_{stg}< 3 μs				3 *			102	
★ 〃 2659A	〃	〃	〃	900	500	7 A	120W (Tc=25°C)	150	100	900	> 8	5	5 A	10	−500	t_{on}<1.2μs, t_f<1.2μs t_{stg}<2.5μs				3.5 *			102	
〃 2660A	〃	PA	Si. TP	200	180	2 A	30W (Tc=25°C)	150	50	150	120	10	150	10	−200					30 *	35	25	268	2SA1133A とコンプリ
〃 2690A	日電	PA. SW	Si. E	160	160	1.2A	20W (Tc=25°C)	150	1	120	140	5	300	5	−200					155 *	19		225	2SA1220A とコンプリ
〃 2749A	〃	SW	Si. T	500	450	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	35	5	1 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}<2.5μs							162	
〃 2751A	〃	〃	〃	500	450	15A	120W (Tc=25°C)	150	100	400	35	5	2 A			t_{on}< 1 μs, t_f<0.7μs t_{stg}<2.5μs							162	
〃 2766A	〃	PA	〃	180	180	15A	150W (Tc=25°C)	150	50	160	150	5	2 A	5	−1A					60 *	180	15	340	
〃 2768A	富士電	SW	Si. TP	250	200	10A	40W (Tc=25°C)	150	100	250	40	5	2 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}< 2 μs							268	
〃 2790A	東芝	〃	Si. T	850	800	2 A	80W (Tc=25°C)	150	100	800	17	5	500			t_r< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							102	
〃 2831A	松下	〃	〃	900	500	1.5A	25W (Tc=25°C)	150	100	900	> 8	5	1 A	10	−200	t_{on}<1.2μs, t_f<1.2μs t_{stg}< 3 μs				2.5 *			268	
〃 2832A	〃	〃	〃	900	500	5 A	40W (Tc=25°C)	150	100	900	> 8	5	3 A	10	−500	t_{on}<1.2μs, t_f<1.2μs t_{stg}< 3 μs				3 *			268	
〃 2833A	〃	〃	Si. TMe	900	500	5 A	70W (Tc=25°C)	150	100	900	> 8	5	3 A	10	−500	t_{on}<1.2μs, t_f<1.2μs t_{stg}<3.0μs				3 *			365	
〃 2834A	〃	〃	Si. T	900	500	7 A	100W (Tc=25°C)	150	100	900	> 8	5	5 A	10	−500	t_{on}<1.2μs, t_f<1.2μs t_{stg}<2.5μs				3.5 *			365	
〃 2865A	新電元	〃	Si. TP	250	225	20A	200W (Tc=25°C)	150	100	250	18	2	10A			t_{on}<0.9μs, t_f<0.4μs t_{stg}<1.5μs							103	
〃 2906A	日電	PA	Si. E	25	12	3 A	35W (Tc=25°C)	200	400	20	60	7	400			P_o= 7 W, η=80% (f=500MHz, V_{CC}=7.2V, P_i=2.8W)					Cre 16		326	
〃 2987A	〃	〃	〃	160	160	12A	120W (Tc=25°C)	150	50	140	130	5	2 A	5	−1A					50 *	190	15	162	2SA1227A とコンプリ
〃 3044A	富士通	SW	Si. EP	450	450	6 A	100W (Tc=25°C)	175	100	450	15	5	3 A	10	−1A	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs				30 *	100		102	
〃 3056A	〃	〃	〃	450	450	6 A	50W (Tc=25°C)	150	100	450	20	5	3 A	10	−1A	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}<1.5μs				30 *	100		268	
〃 3058A	〃	〃	〃	600	450	30A	200W (Tc=25°C)	175	100	500	12	5	20A	10	−4A	t_r<0.5μs, t_f<0.3μs t_{stg}< 2 μs				30 *	420		102	
〃 3211A	松下	〃	Si. TMe	900	500	5 A	70W (Tc=25°C)	150	100	900	13	5	3 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							82	
〃 3212A	〃	〃	〃	900	500	5 A	100W (Tc=25°C)	150	100	900	13	5	5 A			t_{on}< 1 μs, t_f< 1 μs t_{stg}<2.5μs							82	
〃 3242A	三菱	RF. AF. PA	Si. EP	20	20	2 A	900	150	0.2	16	150~500	4	100							80 *	28		6	2SA1282A とコンプリ
〃 3245A	〃	〃	〃	150	150	100	900	150	0.1	100	150~500	10	10							200 *	2.3		6	2SA1285A とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SC3282A	日電	PA	Si. E	35	16	7.5A	70W (Tc=25°C)	200	2 mA	20	50	10	1 A	P_o=18～22～W, η=50～58～% (V_{CC}=13.5V, f=860MHz, P_i=4 W)							25		375A	
〃 3283A	〃	〃	〃	35	16	15A	120W (Tc=25°C)	200	4 mA	20	50	10	2 A	P_o=30～37～W, η=50～55～% (V_{CC}=13.5V, f=860MHz, P_i=8 W)							Cre 50		375A	
〃 3298A	東芝	〃	〃	180	180	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	160	70～240	5	100	10	−100					100*	25		381	2SA1306A とコンプリ
〃 3298B	〃	〃	〃	200	200	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	160	70～240	5	100	10	−100					100*	25		381	2SA1306B とコンプリ
〃 3478A	日電	AF. PA	〃	200	200	100	750	150	0.1	200	135～400	10	10	10	−10	t_{on}=0.15μs t_{off}=1.6μs				160*	2.8		138	2SA1376A とコンプリ
〃 3519A	サンケン	PA	Si. EP	180	180	15A	130W (Tc=25°C)	150	100	180	80	4	5 A	12	−2A					50*	250	10	324	2SA1386A とコンプリ
〃 3547A	東芝	RF	Si. E	20	12	30	150	125	0.1	10	120	10	5	10	−10	NF=2 dB (10V, 5 mA, 1 GHz)				4000*	1.05	$C_c r_{bb'}$ 4.5ps	176	
〃 3547B	〃	〃	〃	20	12	30	150	125	0.1	10	120	10	5	10	−10	〃				4000*	1.05	$C_c r_{bb'}$ 4.5ps	176	
〃 3622A	日電	AF. SW	〃	60	50	150	250	150	0.1	50	1800	5	1	5	−10					250*	3		138	
〃 3623A	〃	〃	〃	60	50	150	250	150	0.1	50	1800	5	1	5	−10					250*	3		42	
〃 3624A	〃	〃	〃	60	50	150	200	150	0.1	50	1800	5	1	5	−10					250*	3		176	
〃 3660A	〃	PA	〃	55	32	24A	320W (Tc=25°C)	200	8 mA	30	60	10	2 A			P_o=91W (f=860MHz, V_{CC}=28V, P_i=25W)					Cre 120		395	
〃 3851A	サンケン	〃	Si. TP	100	80	4 A	25W (Tc=25°C)	150	100	100	100	4	1 A	12	−200					15*	60	30	400	
〃 3852A	〃	〃	〃	100	80	3 A	25W (Tc=25°C)	150	10	100	1000	4	500	12	−200					15*	50	30	400	
〃 3929A	松下	RF	Si. EP	55	55	50	150	150	0.1	10	350	5	2	10	−10					250*	3.5		412	2SA1531A とコンプリ
〃 3940A	〃	〃	〃	60	50	1 A	1 W	150	0.1	20	180	10	500	10	−50					200*	11		413	2SA1534A とコンプリ
〃 3944A	〃	PA	〃	180	180	1 A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	160	10	150	10	−10					300*	20		364	2SA1535A とコンプリ
〃 4181A	日電	SW	Si. E	60	50	150	150	150	0.1	50	1800	5	1			t_{on}<1 μs, t_{off}<2 μs t_{stg}<2 μs							412	
〃 4199A	サンケン	〃	Si. TP	1500	800	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	1200	8	4	5 A			t_{on}<1 μs, t_f<0.3μs t_{stg}<4 μs							172	
〃 4303A	〃	〃	〃	1500	800	6 A	80W (Tc=25°C)	150	100	1200	8	4	2.5A			〃							172	

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
★	2SD51A	ソニー	PA	Si. Me	150	110	5 A	50W (Tc=25°C)	150	100	50	60	3	2 A	10	−500					10 *			102	
	〃 78A	日電	PA. SW	Si. EPa	100	80	2 A	1 W (Tc=25°C)	175	1	80	80	2	500	10	−200								84B	2SB504A とコンプリ
★	〃 88A	ソニー	PA	Si. TMe	100	80	10A	120W (Tc=25°C)	150	100	50	150	3	2 A										102	
★	〃 170A	日立	〃	Ge. A	32	25	500	200	85	20	12	150	1	150										12A	2SB370A とコンプリ
	〃 181A	日電	PA. SW	Si. TMe	250	200	10A	100W (Tc=25°C)	175	1 mA	200	60	5	5 A	10	−200								102	
★	〃 200A	松下	SW	Si. Me	1500	1500S	2.5A	10W (Tc=90°C)	115	1 mA	1500	2.5	5	2 A				t_f=0.7μs						102	
	〃 206A	新電元	PA. SW	Si. DJ	50	30	10A	150W (Tc=25°C)	150	1	30	20	5	5 A	10	−1A					f_{ae} 18kHz			102	
	〃 207A	〃	〃	〃	100	60	10A	150W (Tc=25°C)	150	1	30	20	5	5 A	10	−1A					f_{ae} 18kHz			102	
	〃 208A	〃	〃	〃	150	90	10A	150W (Tc=25°C)	150	1	30	20	5	5 A	10	−1A					f_{ae} 18kHz			102	
★	〃 226A	松下	PA	〃	60	60	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	50	3	1 A	10	−200					f_{ae} 25kHz			99	
★	〃 226B	〃	〃	〃	80	80	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	50	3	1 A	10	−200					f_{ae} 25kHz			99	
★	〃 232A	富士通	SW. AF	Si. TMe	160	140	30A	125W (Tc=25°C)	175	1 mA	50	25	4	10A										102	
★	〃 287A	日電	PA	Si. T	200	120	10A	100W (Tc=25°C)	150	50	120	80	5	2 A	5	−200					15 *	270		102	2SB539A とコンプリ
★	〃 287B	〃	〃	〃	200	140	10A	100W (Tc=25°C)	150	50	120	80	5	2 A	5	−200					15 *	270		102	2SB539B とコンプリ
★	〃 287C	〃	〃	〃	200	150	10A	100W (Tc=25°C)	150	50	120	80	5	2 A	5	−200					15 *	270		102	2SB539C とコンプリ
★	〃 317A	松下	〃	〃	80	80	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	60	3	1 A	10	−200					f_{ae} 25kHz			268	
★	〃 318A	〃	〃	〃	80	80	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	60	3	1 A	10	−200					f_{ae} 25kHz			267	
★	〃 334A	〃	〃	Si. DJ	130	100	6 A	75W (Tc=25°C)	150	1 mA	130	100	4	1 A										102	
	〃 350A	〃	〃	Si. Me	1500	700	5 A	22W (Tc=25°C)	115	100	750	>3	10	4 A			t_f<1 μs							102	
	〃 363A	日電	SW	Si. TMe	350	300	30A	200W (Tc=25°C)	175	100	300	30	5	15A			t_{on}<2 μs, t_{off}<6.5μs t_{stg}<4 μs							106	
★	〃 365A	松下	PA	〃	80	80	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	70	3	1 A							f_{ae} 70kHz			268	2SB512A とコンプリ
★	〃 366A	〃	〃	〃	80	80	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	70	3	1 A							f_{ae} 70kHz			267	2SB513A とコンプリ
	〃 373A	日電	SW	Si. T	350	300	30A	200W (Tc=25°C)	175	100	300	30	5	15A										106	
	〃 376A	〃	PA. SW	〃	350	300	10A	100W (Tc=25°C)	175	100	300	25	5	5 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.4μs t_{stg}=3 μs							102	
	〃 380A	松下	PA	Si. Me	1500	650	5 A	50W (Tc=25°C)	130	1 mA	1500	>7.5	10	5 A			t_f<0.9μs							102	
	〃 386A	三洋	〃	Si. TP	200	150	2 A	25W (Tc=25°C)	150	1 mA	180	40~320	2	500	5	−500					8 *			268	
	〃 387A	〃	〃	〃	200	150	2 A	25W (Tc=25°C)	150	1 mA	180	40~320	2	500	5	−500					8 *			267	
	〃 389A	松下	〃	Si. DJ	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	−200					f_{ae} 25kHz			268	
★	〃 390A	〃	〃	〃	80	80	3 A	25W (Tc=25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	−200					f_{ae} 25kHz			267	
	〃 401A	日電	〃	Si. T	200	150	2 A	25W (Tc=25°C)	150	50	150	90	10	400	10	−400					5 *			268	2SB546A とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	r_{bb} h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD402A	日電	PA	Si.T	200	150	2 A	25W (Tc=25°C)	150	50	150	90	10	400	10	−400					5 *			267	2SB547A とコンプリ
★ 〃 470B	松下	SW	Si.TMe	1600	700	1 A	15W (Tc=25°C)	150	30	750	2 ~ 6	5	1 A			t_{stg}= 7 ~12μs t_f<1.2μs							288	水平偏向用
〃 476A	日立	PA	Si.T	70	60	4 A	40W (Tc=25°C)	150	1	50	60~200	4	1 A	4	−500					7 *			268	2SB566A とコンプリ
〃 538A	富士通	SW	Si.TP	500	400	10A	150W (Tc=25°C)	175	100	150	25	5	5 A			t_r= 1 μs, t_f=0.7μs t_{stg}=1.5μs							102	
〃 539A	〃	〃	〃	400	350	10A	150W (Tc=25°C)	175	100	150	25	5	5 A			t_r= 1 μs, t_f=0.7μs t_{stg}=1.5μs							102	
〃 574A	新電元	PA.SW	Si.DJ	120	120	30A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	120	800	3	15A			t_{on}< 2 μs, t_f< 5 μs t_{stg}<4.5μs							266	ダーリントン
〃 581A	日立	PA	Si.E	150	120	7 A	60W (Tc=25°C)	150	10	120	120	5	1 A										102	
★ 〃 586A	日電	PA.SW	〃	100	100	5 A	60W (Tc=25°C)	150	10	80	80	5	1 A	5	−100					15 *	75		295	2SB616A とコンプリ
★ 〃 587A	〃	PA	Si.T	120	120	6 A	70W (Tc=25°C)	150	50	100	80	5	1 A	5	−200					17 *	130		295	2SB617A とコンプリ
★ 〃 588A	〃	〃	〃	150	130	7 A	80W (Tc=25°C)	150	50	120	80	5	1 A	5	−200					15 *	190		295	2SB618A とコンプリ
〃 592A	松下	AF	Si.EP	60	50	1 A	750	150	0.1	20	160	10	500	10	−50					200 *	20		138	2SB621A とコンプリ
〃 596	日電	〃	Si.E	30	25	700	200	150	0.1	30	200	1	100	6	−10					170 *	12		176	2SB624 とコンプリ
〃 601A	松下	〃	Si.EP	60	50	100	200	125	1	10	160~460	10	2	10	− 2	V_{NO}<300mV (10V, 1 mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				150 *	3.5		176	2SB709A とコンプリ
〃 602A	〃	〃	〃	60	50	500	200	125	0.1	20	160	10	150	10	−50					200 *	6		176	2SB710A とコンプリ
★ 〃 611A	富士通	PA	Si.DJ	120		7 A	30W (Tc=25°C)	175	20	30	>30	4	500							1.5 *			99	
〃 646A	東芝	SW	Si.TMe	600		50A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	600	>150	5	50A			t_{on}= 1 μs, t_f=2.5μs t_{stg}= 8 μs					600		319	
〃 647A	〃	〃	〃	800	600	100A	770W (Tc=25°C)	125	2 mA	800	>100	5	100A			t_{on}=2.5μs, t_f= 4 μs t_{stg}=20μs							158	ダーリントン
〃 648A	〃	〃	〃	300	300	400A	2500W (Tc=25°C)	125	10mA	300	>100	5	400A			t_{on}= 1 μs, t_f= 2 μs t_{stg}= 8 μs							156	〃
〃 666A	日立	PA	Si.E	120	100	50	900	150	10	100	60~200	5	10	5	−10					140 *	3		251	2SB646A とコンプリ
〃 667A	〃	〃	〃	120	100	1 A	900	150	10	100	60~200	5	150	5	−150					140 *	12		251	2SB647A とコンプリ
〃 668A	〃	〃	〃	180	160	50	1 W	150	10	160	60~200	5	10	10	−10					140 *	3.5		160	2SB648A とコンプリ
〃 669A	〃	〃	〃	180	160	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	10	160	60~200	5	150	5	−500					140 *	14		160	2SB649A とコンプリ
★ 〃 673A	〃	〃	Si.T	120	100	7 A	60W (Tc=25°C)	150	1 mA	100	60~200	5	1 A	5	−1A		t_f=0.4μs			50 *			102	2SB653A とコンプリ
★ 〃 674A	〃	〃	〃	120	120	7 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	100	60~200	5	1 A	5	−1A		t_f=0.4μs			50 *			102	2SB654A とコンプリ
★ 〃 675A	〃	〃	〃	160	140	12A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	140	35~200	5	1 A	5	−1A		t_f=0.4μs			50 *			102	2SB655A とコンプリ
★ 〃 676A	〃	〃	〃	160	160	12A	125W (Tc=25°C)	150	1 mA	140	35~200	5	1 A	5	−1A		t_f=0.4μs			50 *			102	2SB656A とコンプリ
★ 〃 678A	松下	〃	Si.EMe	80	80	3 A	25W (Tc=25°C)	150	200	80	2000	3	500	3	−1.5A					f_{ae} 100kHz			268	ダーリントン
★ 〃 679A	〃	〃	〃	90	90	4 A	40W (Tc=25°C)	150	200	90	3000	3	1 A	3	−3A					f_{ae} 100kHz			268	〃
〃 683A	東芝	SW	Si.TMe	600		15A	150W (Tc=25°C)	150	500	600	>500	5	5 A			t_{on}=0.4μs, t_f= 3 μs t_{stg}=15μs					100		102	〃
〃 684A	〃	〃	Si.T	600		6 A	30W (Tc=25°C)	150	500	600	>600	2	2 A			t_{on}= 1 μs, t_f= 5 μs t_{stg}= 8 μs					35		99	〃

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ / f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD696A	東芝	SW	Si.TMe	400		50A	400W (Tc=25°C)	150	1 mA	400	>150	5	50A			t_{on}= 1 μs, t_f=2.5μs t_{stg}= 8 μs					600		319	
〃 697A	〃	〃	〃	500	450	100A	770W (Tc=25°C)	125	2 mA	500	>100	5	100A			t_{on}=2.5μs, t_f= 4 μs t_{stg}=20μs							158	ダーリントン
〃 711A	富士電機	〃	Si.TP	600	600	15A	100W (Tc=25°C)	150	500	600	200	1.7	15A			t_{on}< 3 μs, t_f< 5 μs t_{stg}<15μs							102	ダーリントン
★ 〃 712A	三菱	〃	Si.EP	280	280	4 A	30W (Tc=25°C)	150	30	180	55~300	5	500	5	−500	t_r=0.7μs, t_f=0.6μs t_{stg}=1.5μs				7 *			301B	
★ 〃 736A	日立	PA	Si.T	160	140	12A	100W (Tc=25°C)	150	1 mA	120	60~200	5	1 A	5	−1A		t_f=0.4μs			50 *			332	2SB700A とコンプリ
★ 〃 738A	〃	〃	〃	160	160	12A	125W (Tc=25°C)	150	1 mA	140	60~200	5	1 A	5	−1A		t_f=0.4μs			50 *			332	2SB702A とコンプリ
〃 743A	日電	PA.SW	〃	100	100	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	80	100	5	500	5	−100					17 *	80		268	2SB703A とコンプリ
★ 〃 745A	〃	AF	〃	150	150	10A	120W (Tc=25°C)	150	50	140	80	5	2 A	5	−200					15 *	270		340	2SB705A とコンプリ
〃 745B	〃	〃	〃	160	160	10A	120W (Tc=25°C)	150	50	140	80	5	2 A	5	−200					15 *	270		340	2SB705B とコンプリ
★ 〃 746A	〃	〃	〃	220	220	10A	200W (Tc=25°C)	150	50	180	80	5	2 A	5	−200					15 *	300		265	2SB706A とコンプリ
〃 748A	日立	PA	〃	250	250	3 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	25~200	5	1 A										102	
〃 756A	〃	AF	Si.E	140	140	50	750	150	0.5	100	250~500	12	2	12	− 5					350 *	1.6		251	2SB716A とコンプリ
〃 762A	松下	PA	Si.TM	80	80	4 A	30W (Tc=25°C)	150	30	20	30~160	3	1 A							f_{ae} * 25kHz			268	
〃 772A	〃	〃	Si.TP	200	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	14<	4	5 A			t_f< 1 μs				40 *			268	
〃 772B	〃	〃	〃	250	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	150	14<	4	5 A			t_f< 1 μs				40 *			268	
〃 780A	日電	AF	Si.E	80	80	300	200	150	0.1	80	200	1	50	6	−10					140 *	7		176	2SB736A とコンプリ
〃 794A	〃	PA.SW	〃	70	60	3 A	10W (Tc=25°C)	150	1	45	100	5	500	5	−100					60 *	40		225	2SB744A とコンプリ
〃 795A	〃	PA	〃	50	50	3 A	20W (Tc=25°C)	150	1	40	160	1	500										268	
〃 814A	松下	LN	Si.EP	185	185	50	200	125	1	100	90~450	5	10	10	−10					150 *	2.3		176	
〃 824A	日立	PA	Si.T	120	100	6 A	60W (Tc=25°C)	150	1 mA	100	60~200	5	1 A	5	−1A	t_f=0.4μs				50 *			332	2SB748A とコンプリ
〃 825A	〃	〃	〃	120	120	7 A	80W (Tc=25°C)	150	1 mA	100	60~200	5	1 A	5	−1A	t_f=0.4μs				50 *			332	2SB749A とコンプリ
〃 836A	松下	〃	Si.EP	80	80	2 A	35W (Tc=25°C)	150	1 mA	80	1000~10000	4	1 A			t_{on}=0.4μs, t_{off}= 4 μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 836B	〃	〃	Si.TP	100	100	2 A	35W (Tc=25°C)	150	1 mA	100	4000	4	2 A										268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 837A	〃	〃	〃	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	200	80	1000~10000	3	3 A			t_{on}=0.3μs, t_{off}= 4 μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
〃 837B	〃	〃	Si.EP	100	100	4 A	40W (Tc=25°C)	150	200	100	1000~10000	3	3 A			t_{on}=0.3μs, t_{off}= 4 μs							268	ダーリントン ダンパ内蔵
★ 〃 848A	日電	〃	Si.T	130	130	7 A	80W (Tc=25°C)	150	50	120	80	5	1 A										295	
★ 〃 855A	松下	〃	Si.EP	80	80	1 A	30W (Tc=25°C)	150	200	80	120	4	200										268	2SB760A とコンプリ
〃 855B	〃	〃	〃	100	100	1 A	30W (Tc=25°C)	150	200	100	120	4	200										268	
〃 856A	〃	〃	〃	80	80	3 A	35W (Tc=25°C)	150	200	80	100	4	1 A										268	2SB761A とコンプリ
〃 856B	〃	〃	〃	100	100	3 A	35W (Tc=25°C)	150	200	100	100	4	1 A										268	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	f_{ab} f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	r_{bb} h_{ie} real* (Ω)	外形	備考
2SD857A	松下	PA	Si.EP	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	400	80	100	4	1 A										268	2SB762A とコンプリ
〃 857B	〃	〃	〃	100	100	4 A	40W (Tc=25°C)	150	400	100	100	4	1 A										268	
〃 858A	〃	〃	〃	80	80	5 A	60W (Tc=25°C)	150	400	80	120	4	1 A										365	2SB763A とコンプリ
〃 858B	〃	〃	〃	100	100	5 A	60W (Tc=25°C)	150	400	100	120	4	1 A										365	
〃 859A	〃	〃	〃	400	300	750	35W (Tc=25°C)	150	1 mA	400	120	10	300										268	
〃 859B	〃	〃	〃	450	350	750	35W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	120	10	300										268	
〃 860A	〃	〃	〃	400	300	1 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	400	120	10	300										268	
〃 860B	〃	〃	〃	450	350	1 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	120	10	300										268	
★ 〃 861A	〃	〃	〃	400	300	1.5A	45W (Tc=25°C)	150	1 mA	400	120	10	300										268	
〃 861B	〃	〃	〃	450	350	1.5A	45W (Tc=25°C)	150	1 mA	450	120	10	300										268	
〃 866A	〃	SW	〃	150	100	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	60~260	2	3 A	10	−500		t_f=0.1μs			30 *			268	
〃 874A	〃	AF	〃	60	50	1 A	500	150	0.1	20	60~340	10	500							200 *	15		336	2SB766A とコンプリ
★ 〃 883A	日電	PA	Si.T	120	120	6 A	70W (Tc=25°C)	150	50	100	80	5	1 A										295	
〃 891A	松下	AF	Si.EP	60	50	200	250	150	0.1	25	2000~20000	10	200										138	ダーリントン
〃 892A	〃	〃	〃	60	50	500	400	150	0.1	25	2000~20000	10	500										138	ダーリントン
〃 893A	〃	〃	〃	60	50	1 A	750	150	0.1	45	2000~20000	10	1 A										138	ダーリントン
〃 897A	日立	SW	〃	1500	1500S	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 100	1500	8	5	300				t_f< 1 μs						102	水平偏向用 ダンパ内蔵
〃 898A	〃	〃	〃	1500	1500S	3 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1500							t_f<0.8μs						102	水平偏向用 ダンパ内蔵
〃 898B	〃	〃	Si.T	1500	1500S	3 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1500							t_f<0.8μs						102	水平偏向用 ダンパ内蔵
〃 899A	〃	〃	Si.EP	1500	1500S	4 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1500							t_f< 1 μs						102	水平偏向用 ダンパ内蔵
★ 〃 900A	〃	〃	〃	1500	1500S	5 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1500							t_f<1.2μs						102	水平偏向用 ダンパ内蔵
〃 900B	〃	〃	Si.T	1500	1500S	5 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1500							t_f< 1 μs						102	水平偏向用 ダンパ内蔵
〃 946A	松下	AF	Si.EP	60	50	1 A	1.2W	150	0.1	25	2000~20000	10	1 A										222	ダーリントン 2SB895A とコンプリ
〃 957A	日立	SW	Si.T	1500	1500S	6 A	50W (Tc=25°C)	150	I_{CES} 500	1500							t_f<1.2μs						102	水平偏向用 ダンパ内蔵
〃 968A	松下	AF	Si.EP	120	120	500	500	150			65~330	10	150							120 *	20		336	
〃 973A	〃	〃	〃	60	25	1 A	1 W	150	0.1	20	85~340	10	500	10	−50					200 *	11		151	2SB793A とコンプリ
★ 〃 976A	日立	SW	Si.T	350	150	7 A	50W (Tc=25°C)	150	5 mA	350	>25	5	5 A				t_f<0.5μs						268	水平偏向用
★ 〃 1032A	松下	PA	Si.TP	80	80	4 A	60W (Tc=25°C)	150	400	80	100	4	1 A										365	
★ 〃 1032B	〃	〃	〃	100	100	4 A	60W (Tc=25°C)	150	400	100	100	4	1 A										365	
〃 1034A	東芝	SW	Si.TMe	600	450	300A	1250W (Tc=25°C)	125	2 mA	600	>150	5	300A			t_{on}= 2 μs, t_f= 4 μs t_{stg}= 8 μs							356	ダーリントン

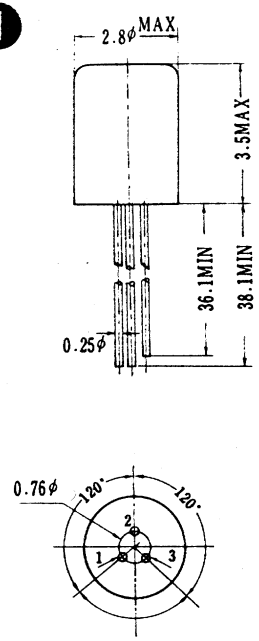
型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1040A	富士通	PA. SW	Si. P	150	120	15A	120W (Tc=25°C)	175	1	80	85	4	2 A			t_r< 3 μs, t_f< 5 μs t_{stg}< 5 μs							102	
★ 〃 1044A	松下	PA	Si. DJ	170	170	6 A	60W (Tc=25°C)	150	10	170	4000	4	1 A										365	ダーリントン
〃 1052A	東芝	〃	Si. T	50	50	3 A	30W (Tc=25°C)	150	100	50	800	5	500										268	
〃 1109A	日電	〃	〃	120	120	6 A	70W (Tc=25°C)	150	50	100	80	5	1 A	5	−200					17 *	130		162	
〃 1110A	〃	〃	〃	130	130	7 A	80W (Tc=25°C)	150	50	120	80	5	1 A	5	−200					15 *	190		162	2SB849Aとコンプリ
〃 1117A	富士電機	〃	Si. TP	80	80	10A	50W (Tc=25°C)	150	10	80	120	5	2 A										268	
〃 1163A	日立	SW	Si. T	350	150	7 A	40W (Tc=25°C)	150	5 mA	350	40	5	5 A				t_f<0.5μs						268	水平偏向用
〃 1165A	東芝	〃	Si. TMe	1000	900	100A	1250W (Tc=25°C)	125	2 mA	1000	>60	5	100A			t_{on}= 1 μs, t_f= 3 μs t_{stg}=20μs							356	ダーリントン
〃 1176A	松下	〃	Si. P	80	80	8 A	45W (Tc=25°C)	150	100	80	1000～10000	3	4 A			t_{on}=0.5μs, t_f= 1 μs t_s= 4 μs							268	ダーリントン 2SB872Aとコンプリ
〃 1198A	〃	AF	Si. EP	60	50	1 A	750	150	0.1	45	2000～20000	10	1 A										151	ダーリントン
〃 1205A	〃	〃	〃	60	50	500	400	150	0.1	25	2000～20000	10	500										151	ダーリントン
〃 1241A	〃	AF. PA	Si. DJ	80	80	5 A	60W (Tc=25°C)	150	30	20	80	3	1 A										365	
〃 1242A	〃	〃	〃	80	80	6 A	70W (Tc=25°C)	150	30	20	80	3	2 A										365	
〃 1243A	〃	〃	〃	80	80	10A	100W (Tc=25°C)	150	30	20	80	3	3 A										365	
〃 1249A	〃	PA	Si. TP	400	300	750	35W (Tc=25°C)	150			40～250	10	300			t_{on}=0.5μs, t_f=0.5μs t_s=2.0μs							363	
〃 1250A	〃	〃	〃	200	180	2 A	30W (Tc=25°C)	150	50	200	60～240	10	150										363	2SB928Aとコンプリ
〃 1251A	〃	〃	Si. T	80	80	4 A	30W (Tc=25°C)	150	30	20	30～160	3	1 A	10	−200					f_{ae} 25kHz			363	
〃 1252A	〃	〃	Si. TP	80	80	3 A	35W (Tc=25°C)	150	200	80	100	4	1 A										363	
〃 1253A	〃	〃	〃	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150			40～250	4	1 A			t_{on}=0.4μs, t_f=0.5μs t_s=1.2μs							363	2SB930Aとコンプリ
〃 1257A	〃	SW	Si. EP	150	100	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	60～260	2	3 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.1μs t_s=1.5μs				30 *			363	2SB934Aとコンプリ
〃 1259A	〃	PA	Si. TP	100	80	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	500～1500	4	500	12	−200					50 *			363	
〃 1260A	〃	〃	〃	80	80	2 A	35W (Tc=25°C)	150	1 mA	80	1000～10000	4	2 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.0μs t_s=4.0μs							363	ダーリントン 2SB937Aとコンプリ
〃 1261A	〃	〃	〃	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	200	80	1000～10000	3	3 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.0μs t_s=4.0μs							363	ダーリントン 2SB938Aとコンプリ
〃 1262A	〃	〃	〃	80	80	8 A	45W (Tc=25°C)	150	100	80	1000～10000	3	4 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.0μs t_s=4.0μs							363	ダーリントン 2SB939Aとコンプリ
〃 1263A	〃	〃	〃	400	300	750	35W (Tc=25°C)	150			40～250	10	300			t_{on}=0.5μs, t_f=0.5μs t_s=2.0μs							364	
〃 1264A	〃	〃	〃	200	180	2 A	30W (Tc=25°C)	150	50	200	60～240	10	150										364	
〃 1265A	〃	〃	Si. T	80	80	4 A	30W (Tc=25°C)	150	30	20	30～160	3	1 A	10	−200					f_{ae} 25kHz			364	
〃 1266A	〃	〃	〃	80	80	3 A	35W (Tc=25°C)	150			40～250	4	1 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.4μs t_s=2.5μs							364	
〃 1267A	〃	〃	〃	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150			40～250	4	1 A										364	
〃 1271A	〃	SW	Si. EP	150	100	7 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	60～260	2	3 A			t_{on}=0.5μs, t_f=0.1μs t_s=1.5μs				30 *			364	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流またはパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T* (MHz)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SD1273A	松下	PA	Si.TP	100	80	3 A	40W (Tc=25°C)	150	100	100	500~1500	4	500	12	−200					50 *			364	
〃 1274A	〃	PA.SW	〃	200	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	200	14~100	4	5 A			t_{stg}< 6 μs, t_f< 1 μs							364	
〃 1274B	〃	〃	〃	250	80	5 A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	250	14~100	4	5 A			t_{stg}< 6 μs, t_f< 1 μs							364	
〃 1275A	〃	PA	〃	80	80	2 A	35W (Tc=25°C)	150	1 mA	80	1000~10000	4	2 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.0μs t_s=4.0μs							364	
〃 1276A	〃	〃	〃	80	80	4 A	40W (Tc=25°C)	150	200	80	1000~10000	3	3 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.0μs t_s=4.0μs							364	
〃 1277A	〃	SW	〃	80	80	8 A	45W (Tc=25°C)	150	100	80	1000~10000	3	4 A			t_{on}=0.5μs, t_f=1.0μs t_s=4.0μs							364	
〃 1336A	〃	AF.PA	Si.T	250	200	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	250	3000	4	3 A										364	ダーリントンダンパ内蔵
〃 1366A	日立	APA	Si.E	30	25	1 A	1 W (プリント基板使用)	150	0.1	20	85~240	2	500	2	−500					240 *	22		336	2SB1000Aとコンプリ
〃 1562A	ローム	PA	Si.EP	160	160	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	120	60~200	5	100	5	−100					80 *	20		268	2SB1085Aとコンプリ
〃 1615A	日電	AF.PA	Si.E	120	60	1 A	2 W (セラミック基板使用)	150	0.1	120	290	2	100	2	−100					160 *	19		336	2SB1115Aとコンプリ
〃 1616A	〃	PA.SW	〃	120	60	1 A	750	150	0.1	60	135~400	2	100	2	−100					160 *	19		138	2SB1116Aとコンプリ
〃 1763A	ローム	PA	Si.EP	160	160	1.5A	20W (Tc=25°C)	150	1	120	60~200	5	100	5	−100					80 *	20		405	2SB1186Aとコンプリ
〃 1819A	松下	AF	〃	60	50	100	150	150	0.1	20	200	10	2							150 *	3.5		412	2SB1218Aとコンプリ
〃 1820A	〃	〃	〃	60	50	500	150	150	0.1	20	170	10	150							200 *	6		412	2SB1219Aとコンプリ
〃 1821A	〃	〃	〃	185	185	50	150	150	1	100	200	5	10							150 *	2.3		412	2SB1220Aとコンプリ

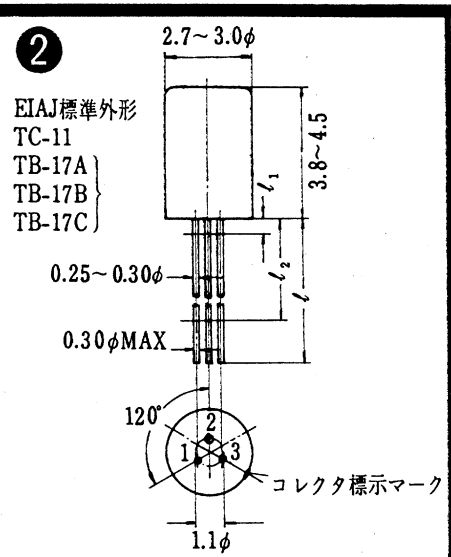
このページは空白です.

外形寸法図

❶

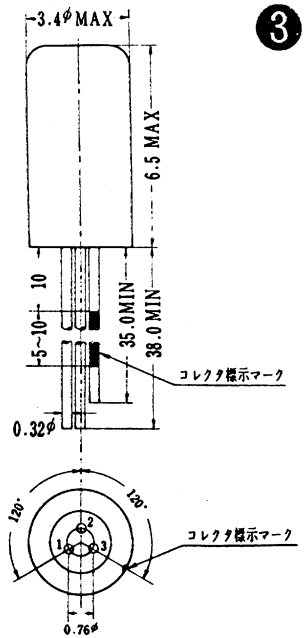


❷

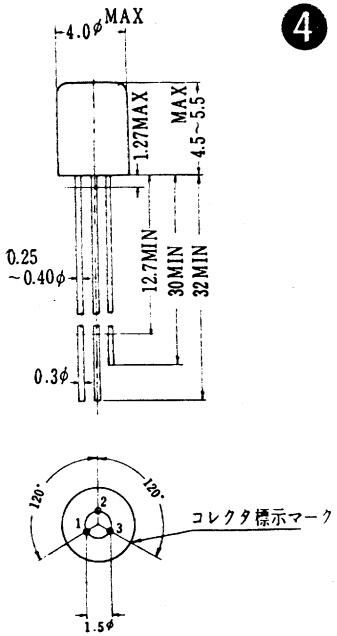


照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ1	1.5 MAX	1.5 MAX	1.5 MAX
ℓ2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

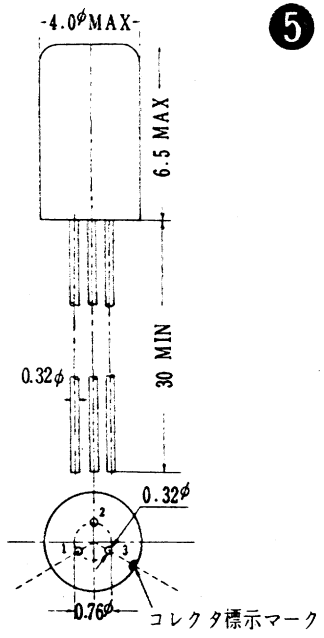
❸



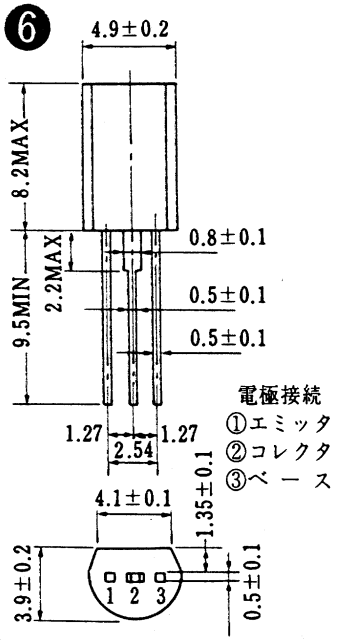
❹



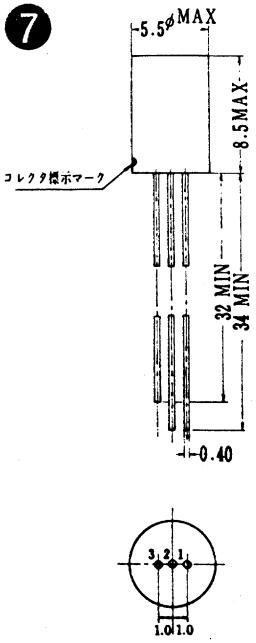
❺



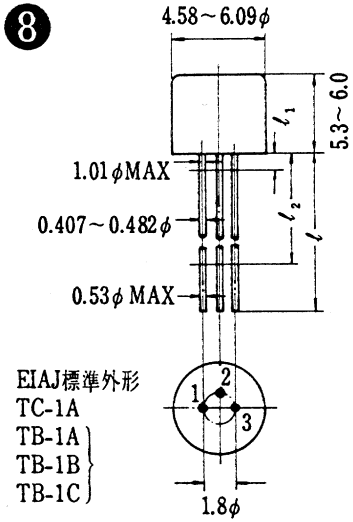
❻



❼

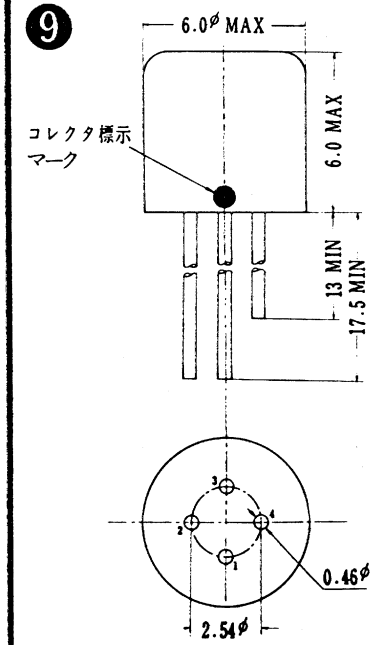


❽

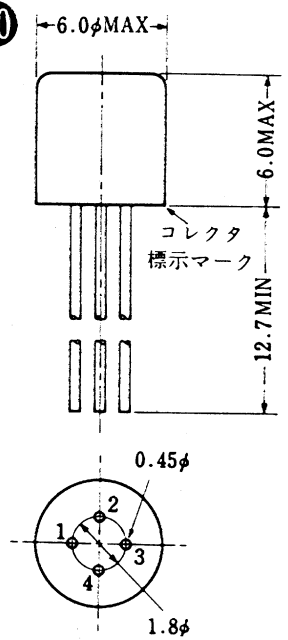


照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

❾



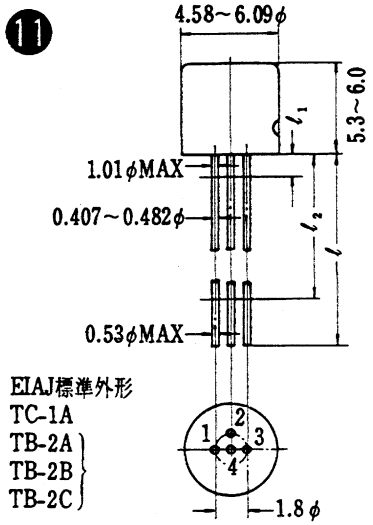
❿



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

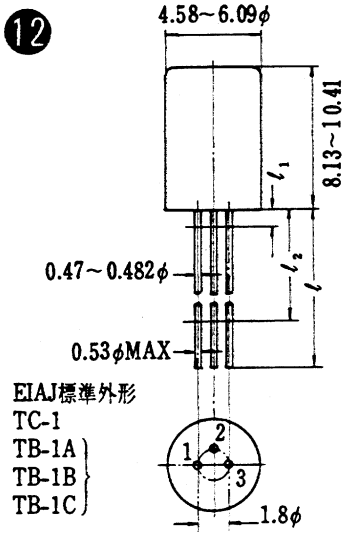
《寸法図単位：mm》

⑪



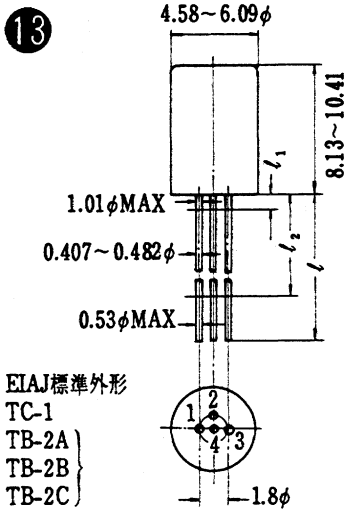
黒合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

⑫



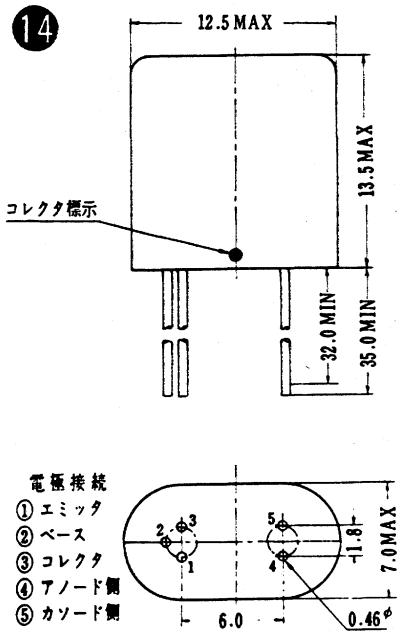
黒合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

⑬

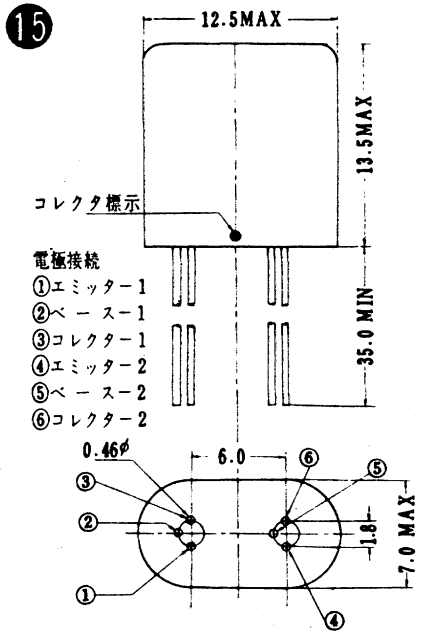


黒合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

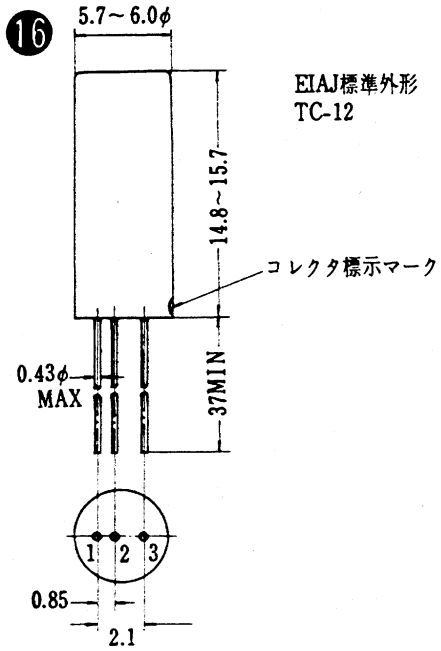
⑭



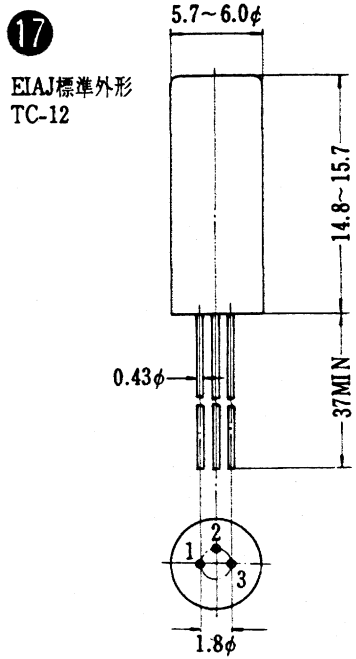
⑮



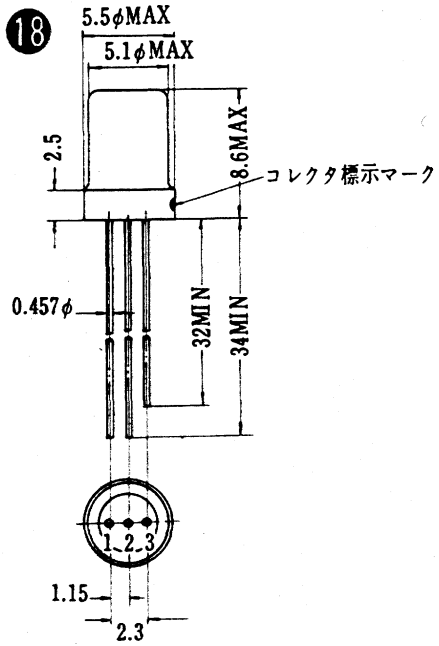
⑯



⑰



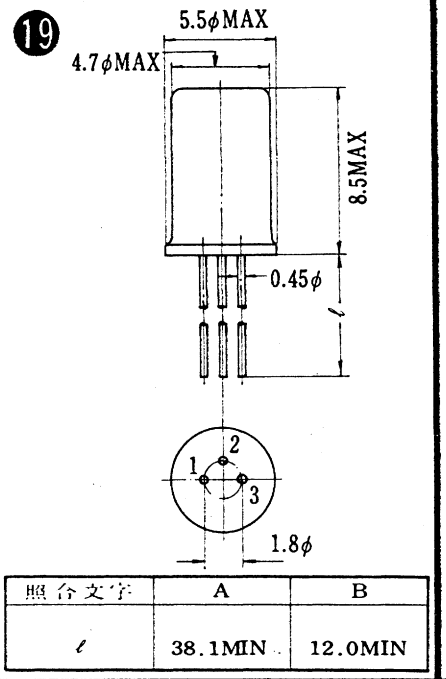
⑱

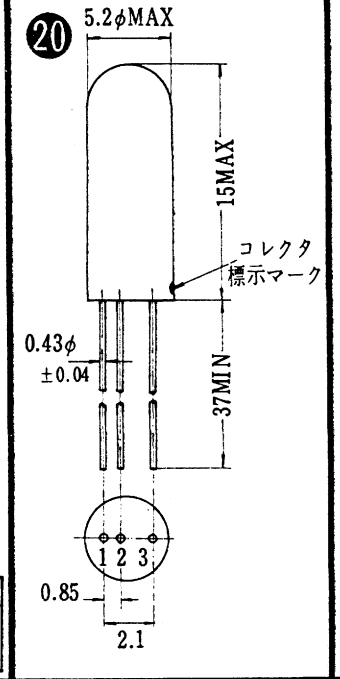


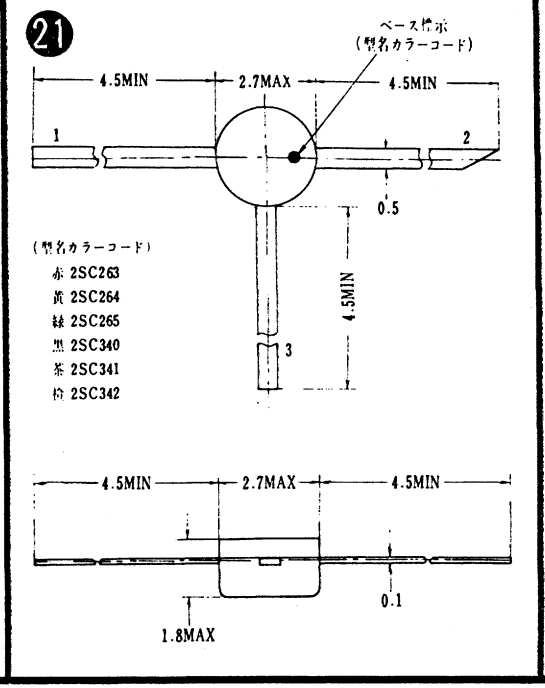
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

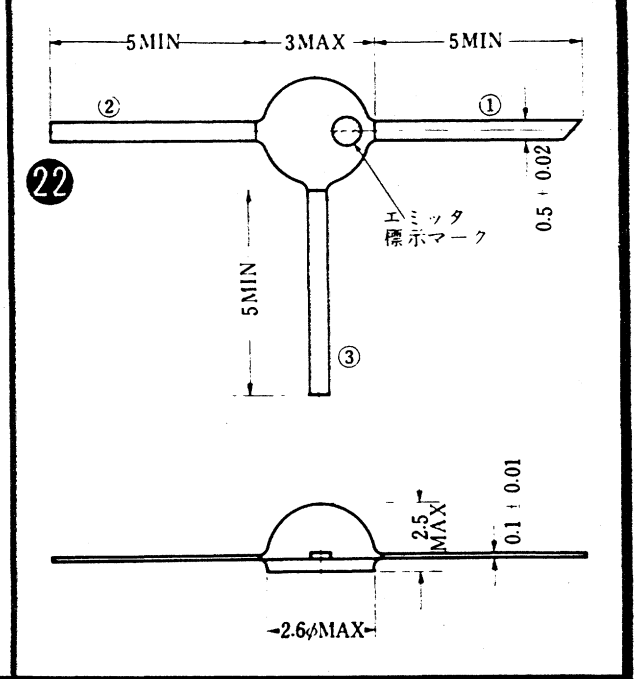
《寸法図単位：mm》

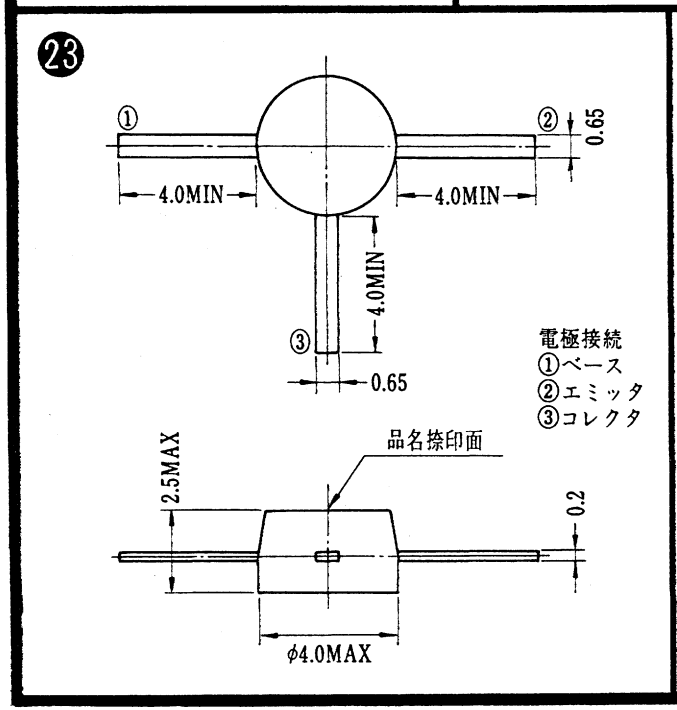
外形寸法図

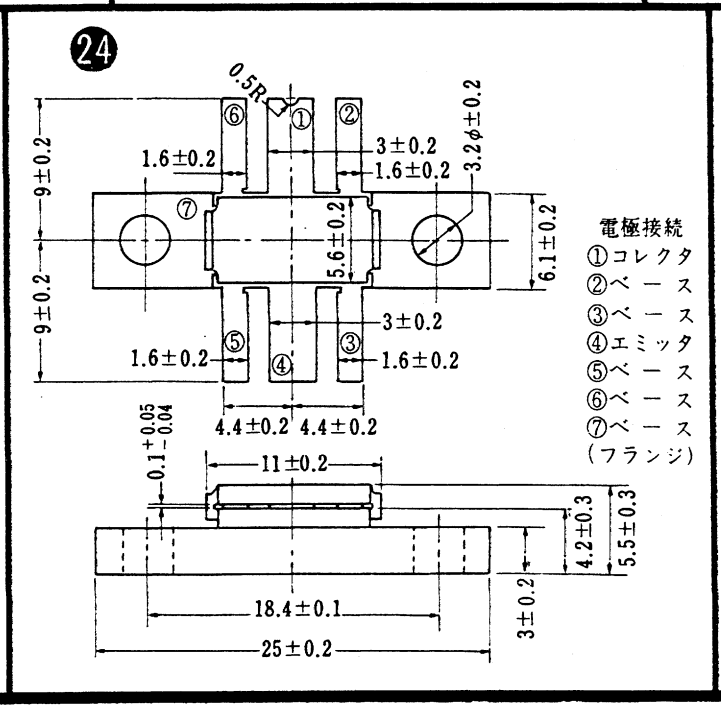


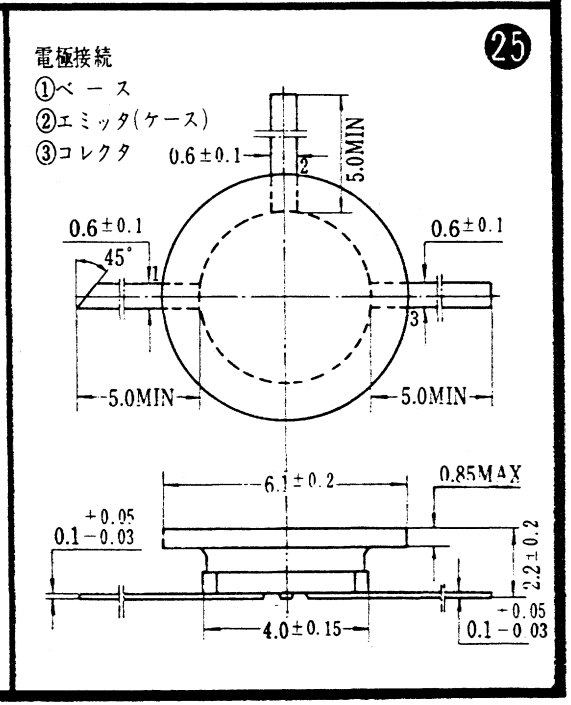






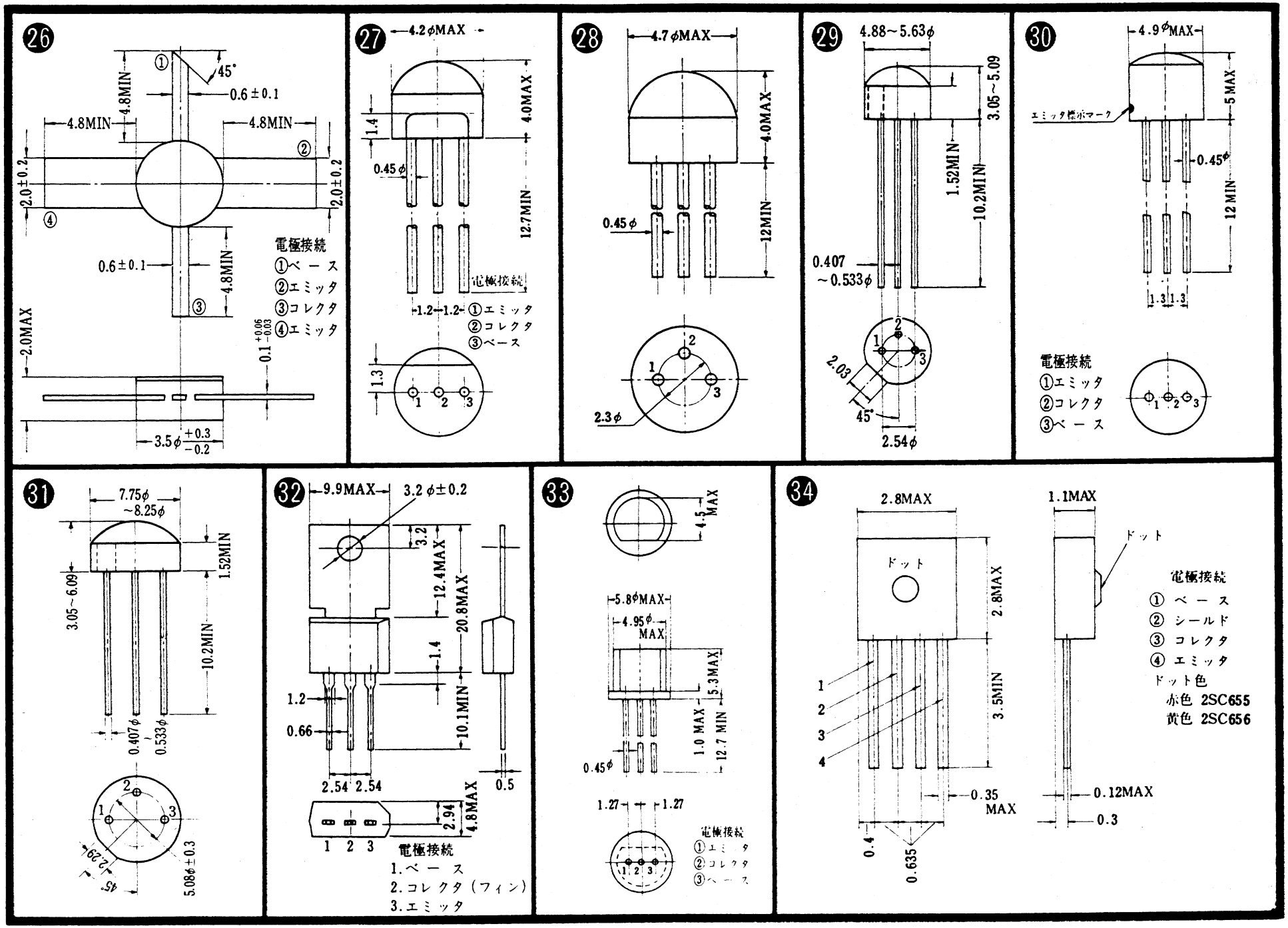






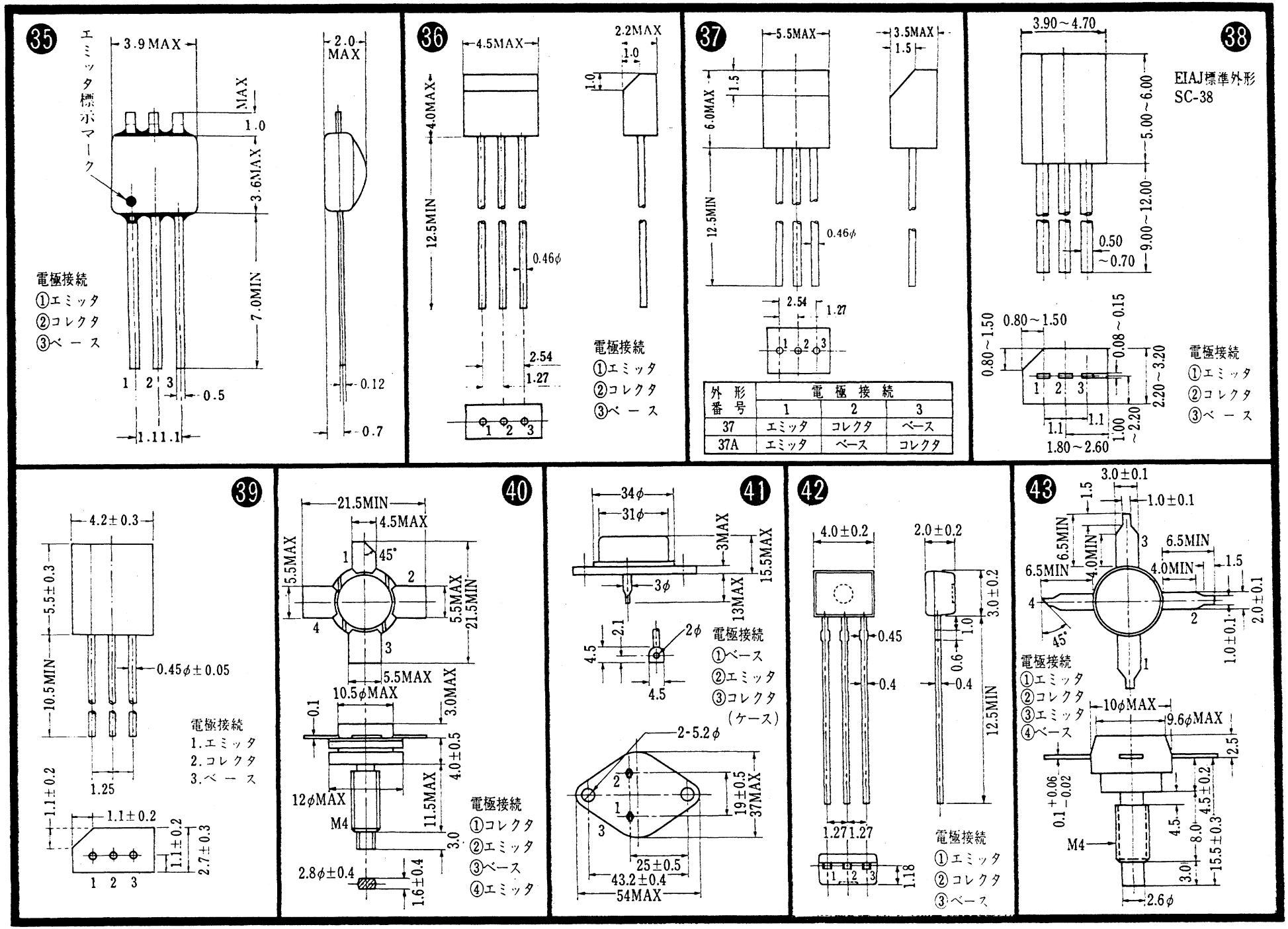
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

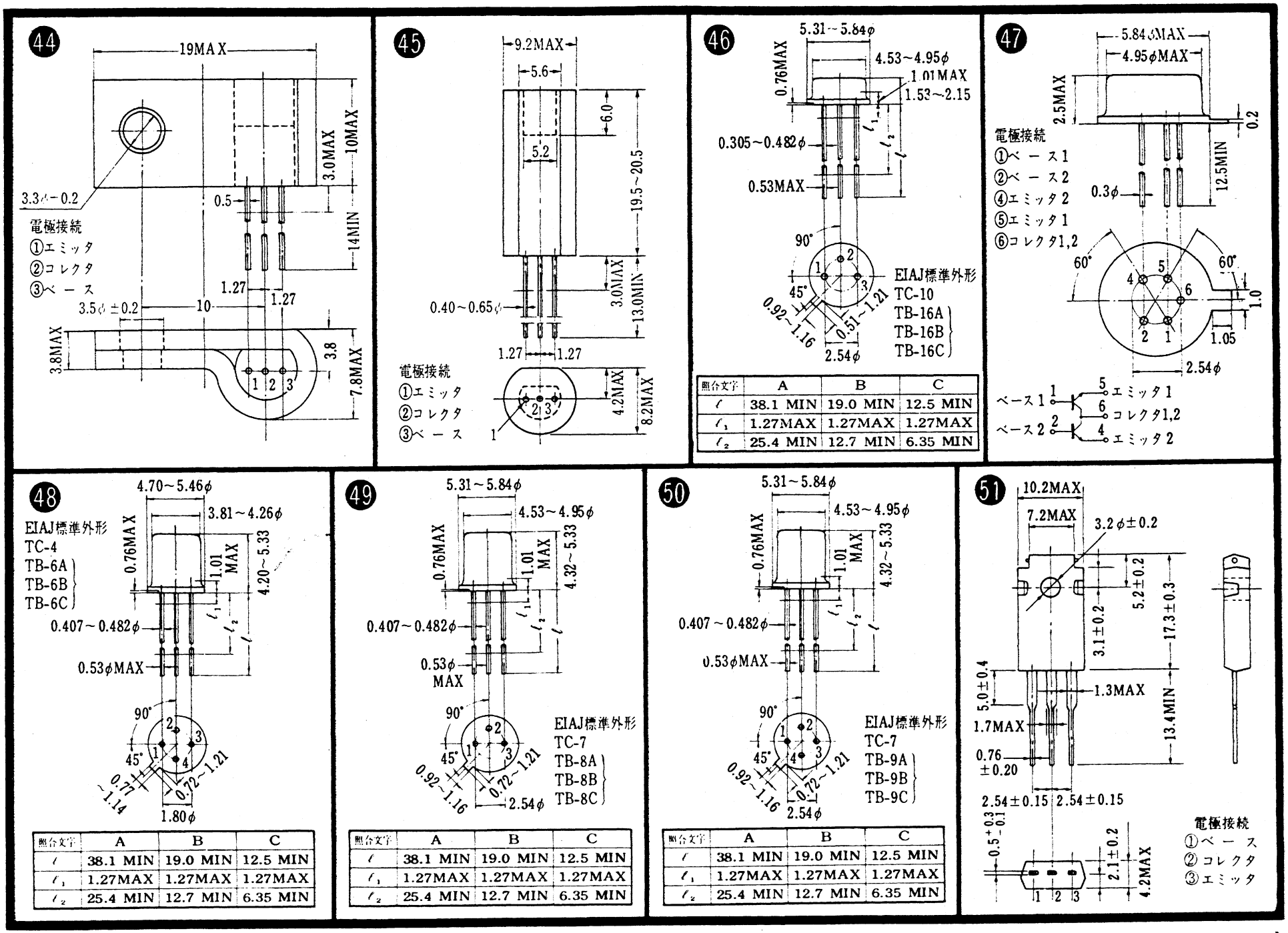
〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

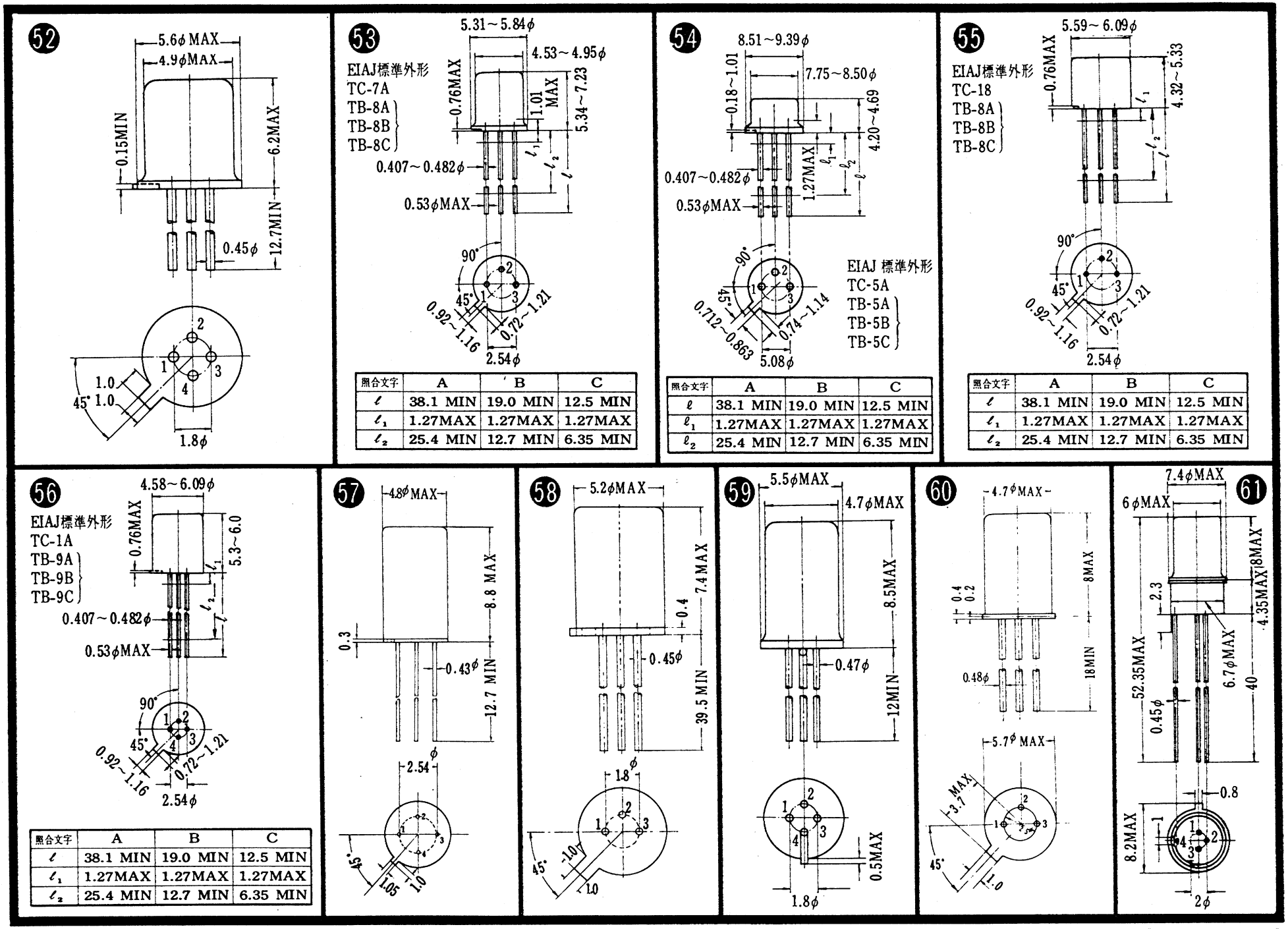
〈寸法図単位：mm〉

外形番号	電極接続 1	2	3
37	エミッタ	コレクタ	ベース
37A	エミッタ	ベース	コレクタ



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

《寸法図単位：mm》



照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

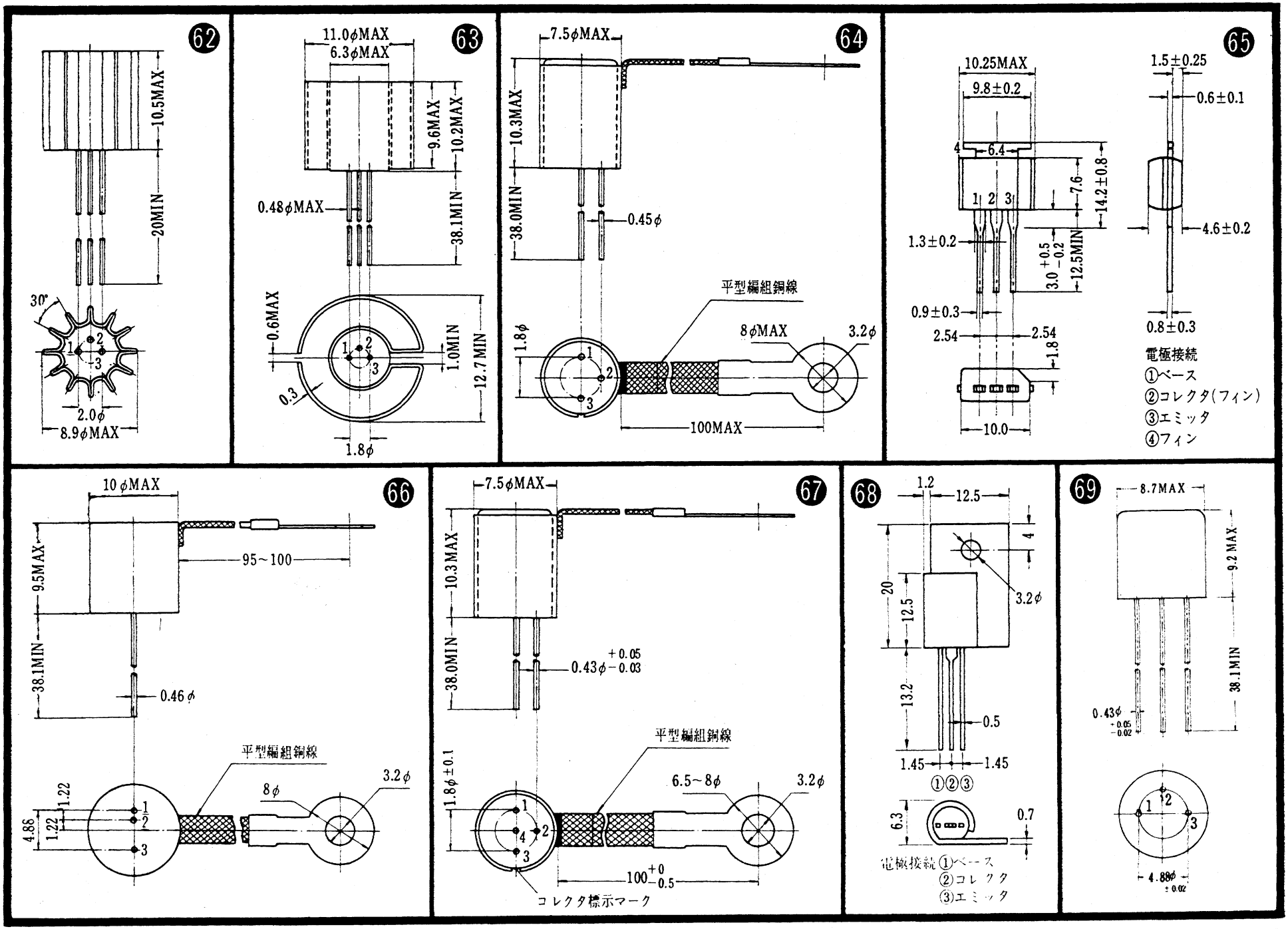
照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

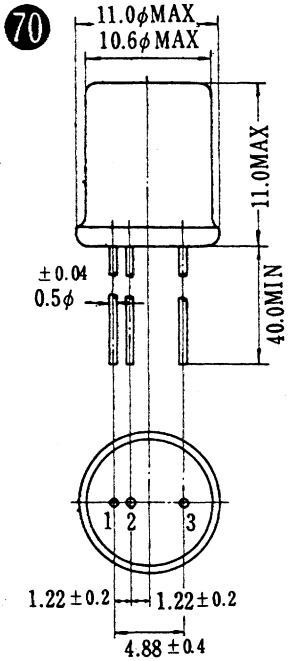
〈寸法図単位：mm〉



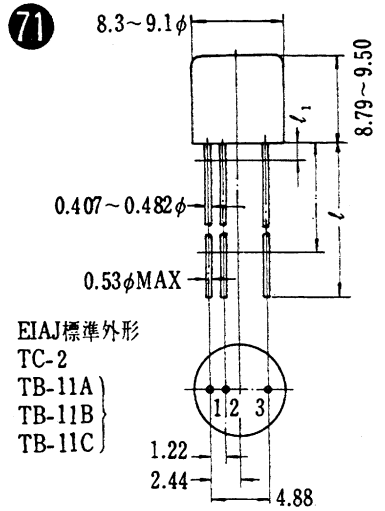
● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉

70

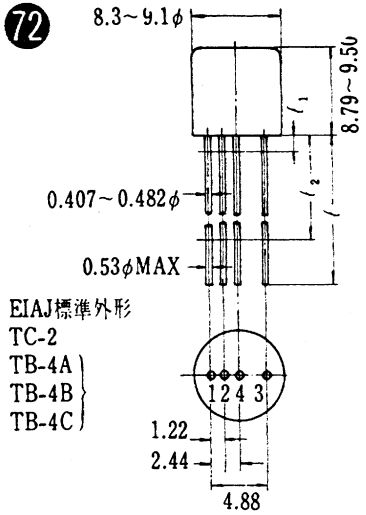


71



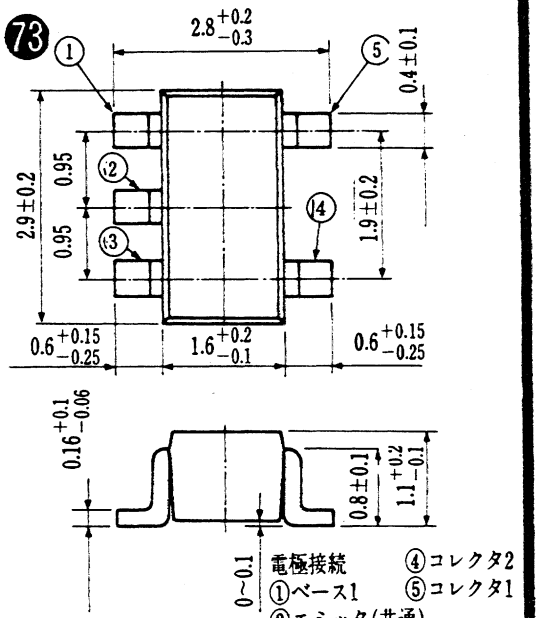
照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

72

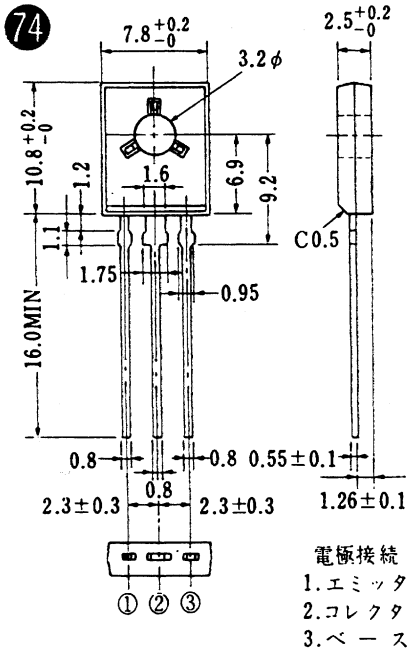


照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

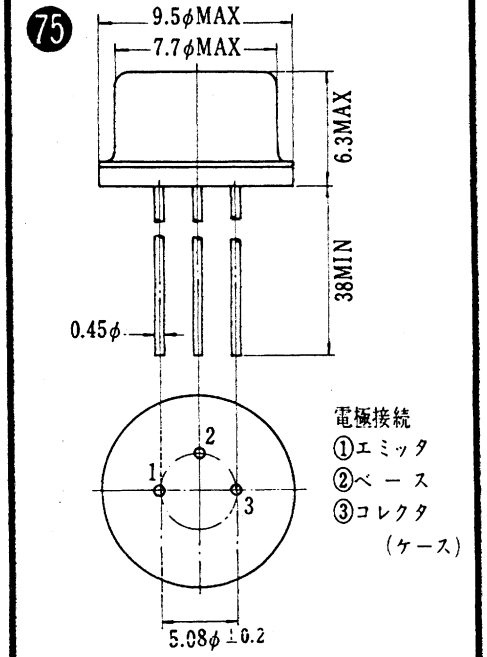
73



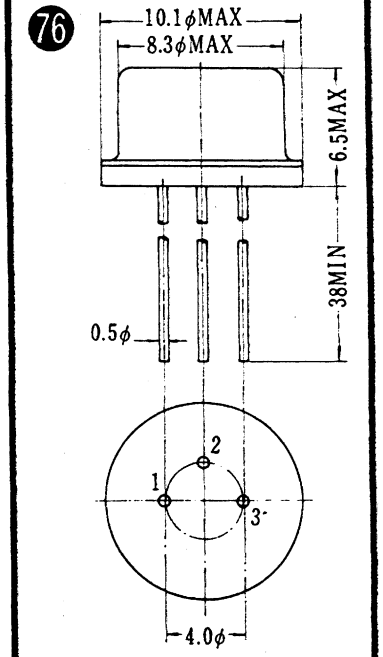
74



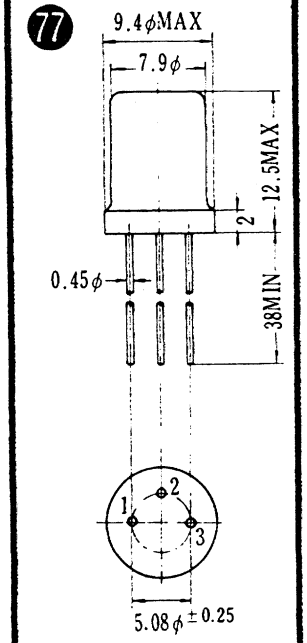
75



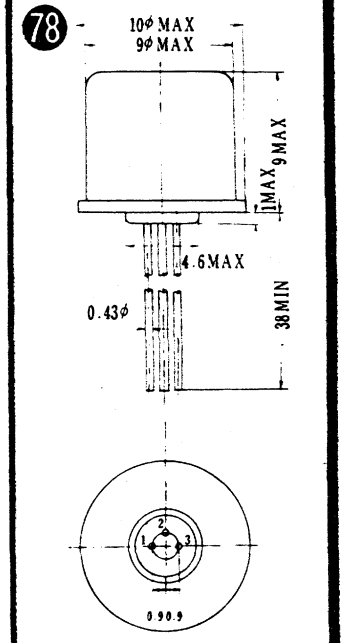
76



77

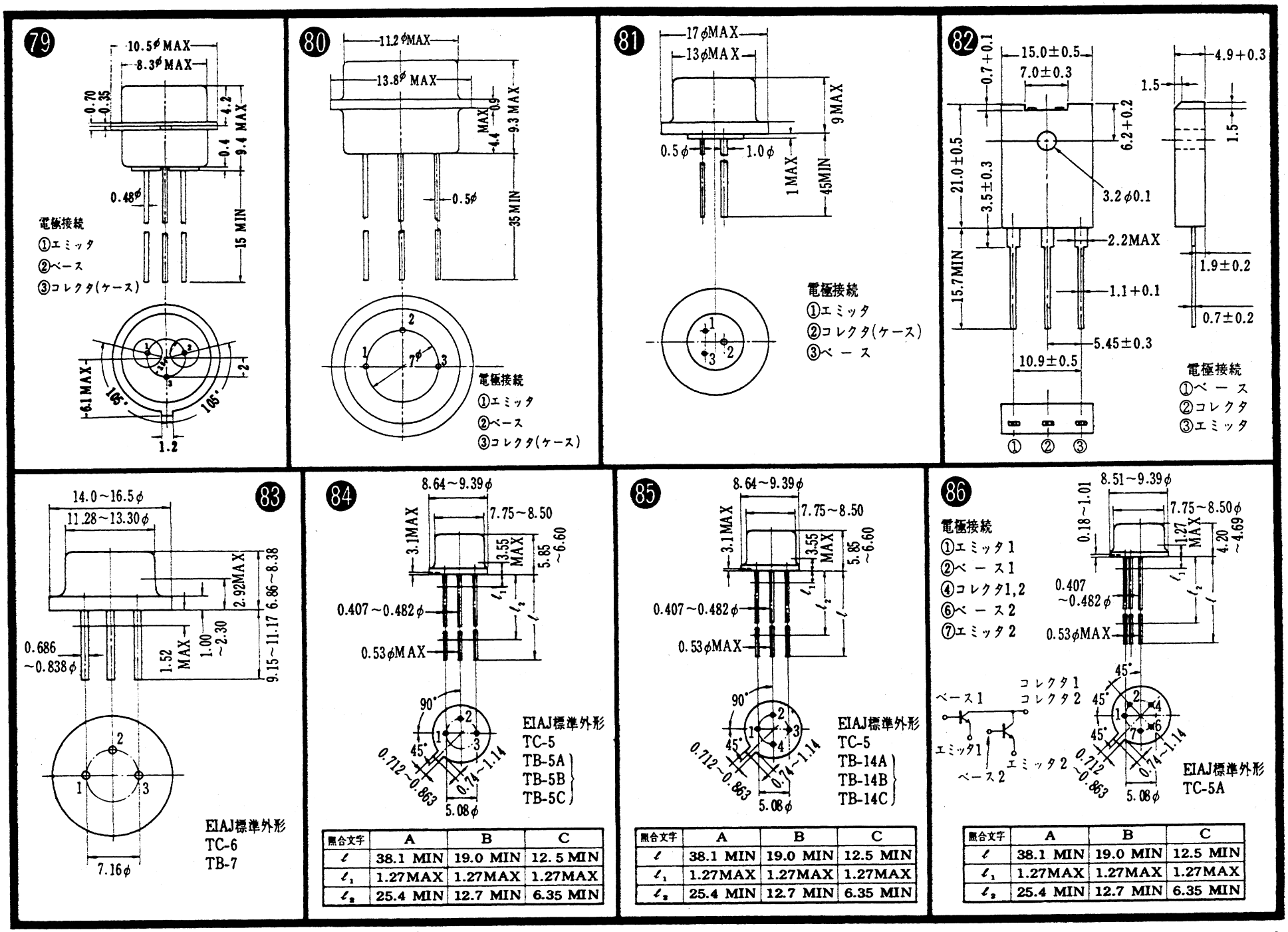


78



● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



黒合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

黒合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

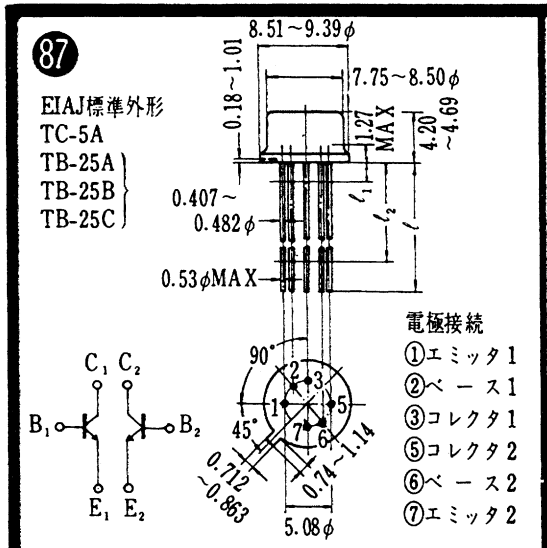
黒合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉

87

EIAJ標準外形
TC-5A
TB-25A
TB-25B
TB-25C

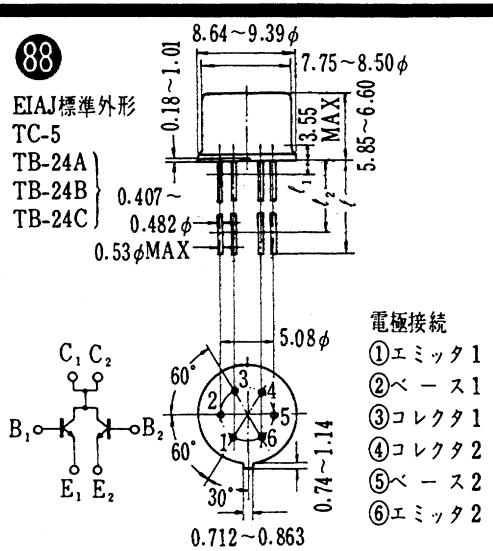


電極接続
①エミッタ1
②ベース1
③コレクタ1
⑤コレクタ2
⑥ベース2
⑦エミッタ2

照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

88

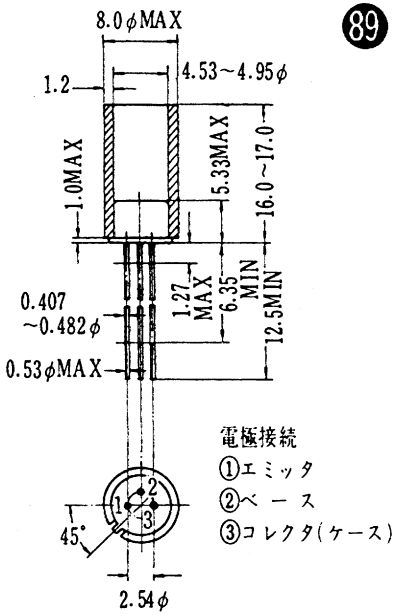
EIAJ標準外形
TC-5
TB-24A
TB-24B
TB-24C



電極接続
①エミッタ1
②ベース1
③コレクタ1
④コレクタ2
⑤ベース2
⑥エミッタ2

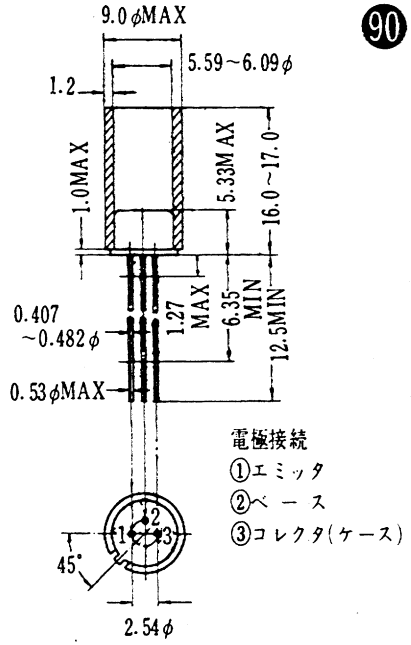
照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

89



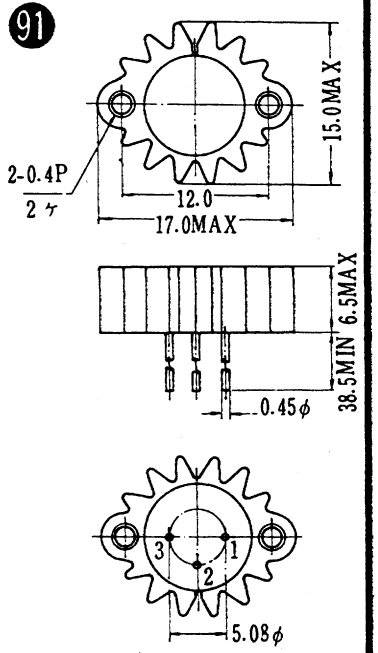
電極接続
①エミッタ
②ベース
③コレクタ(ケース)

90

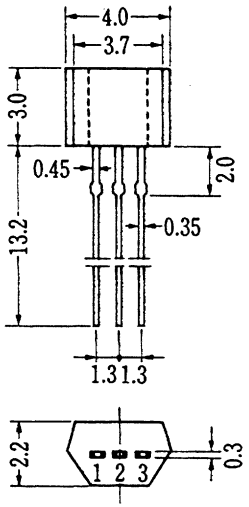


電極接続
①エミッタ
②ベース
③コレクタ(ケース)

91

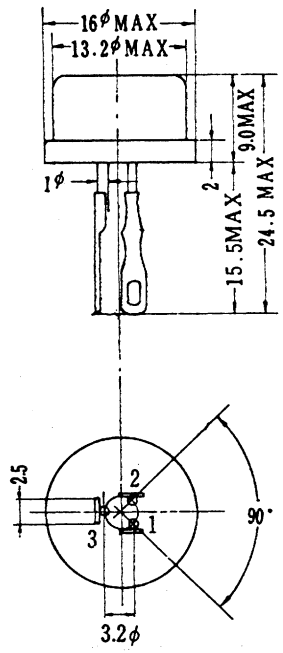


92

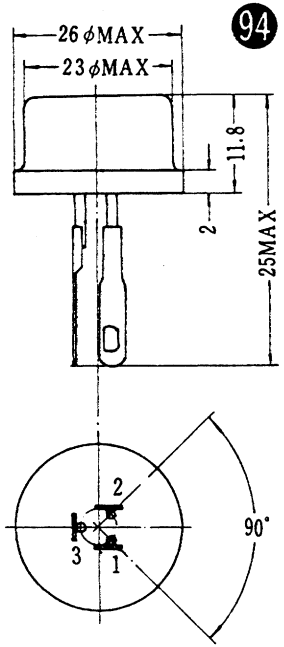


外形番号	電極接続		
	1	2	3
92	エミッタ	コレクタ	ベース
92B	ベース	コレクタ	エミッタ
92C	ベース	エミッタ	コレクタ

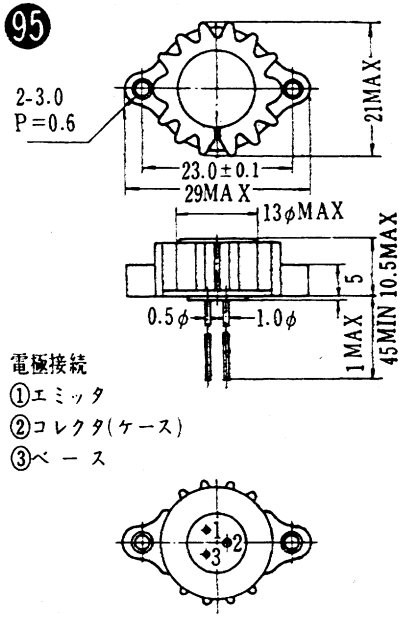
93



94



95

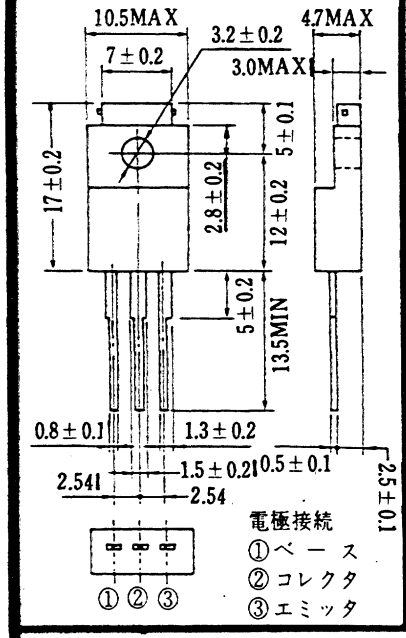


電極接続
①エミッタ
②コレクタ(ケース)
③ベース

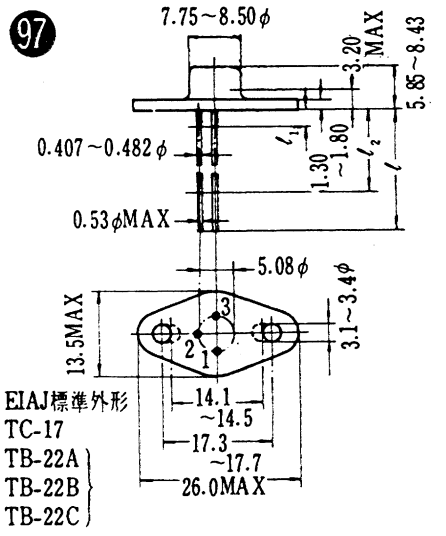
● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

《寸法図単位：mm》

96

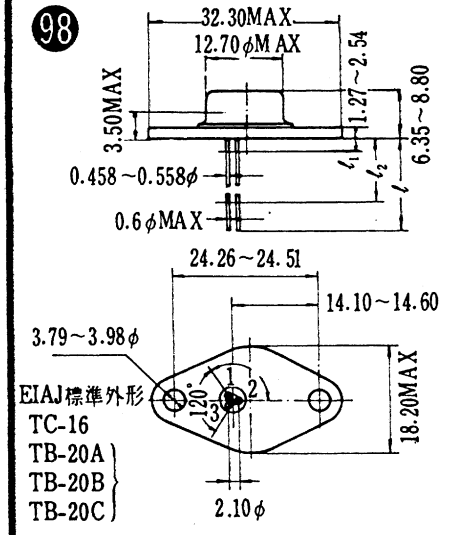


97



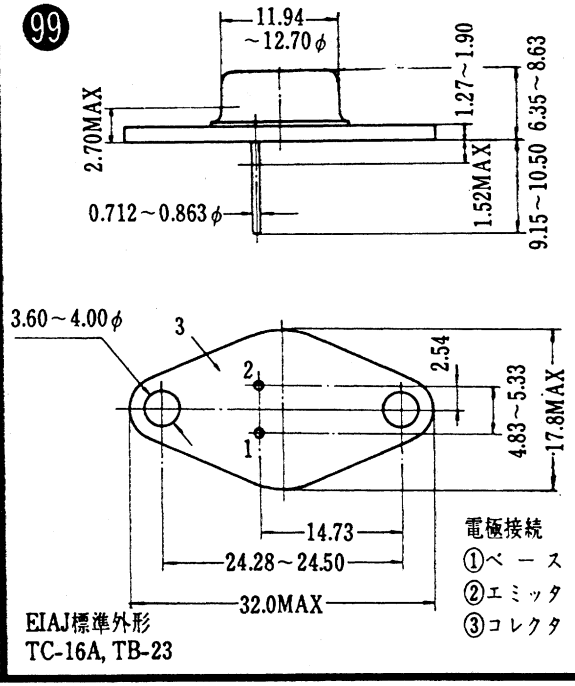
照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

98

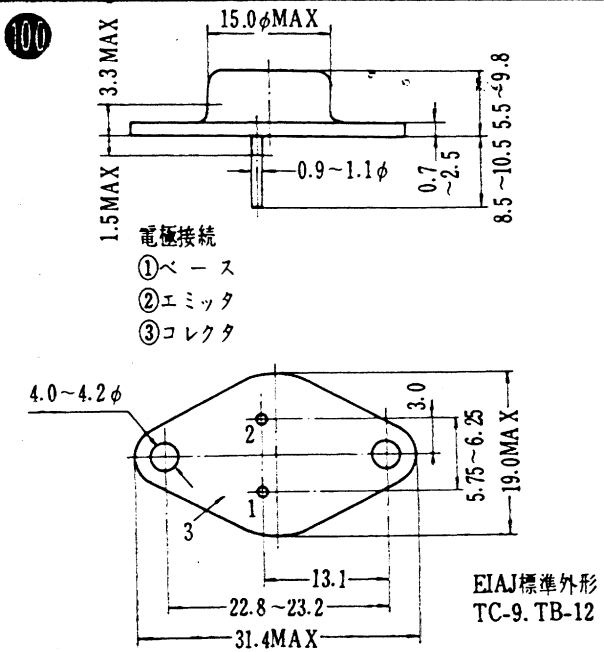


照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27~2.54	1.27~2.54	1.27~2.54
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

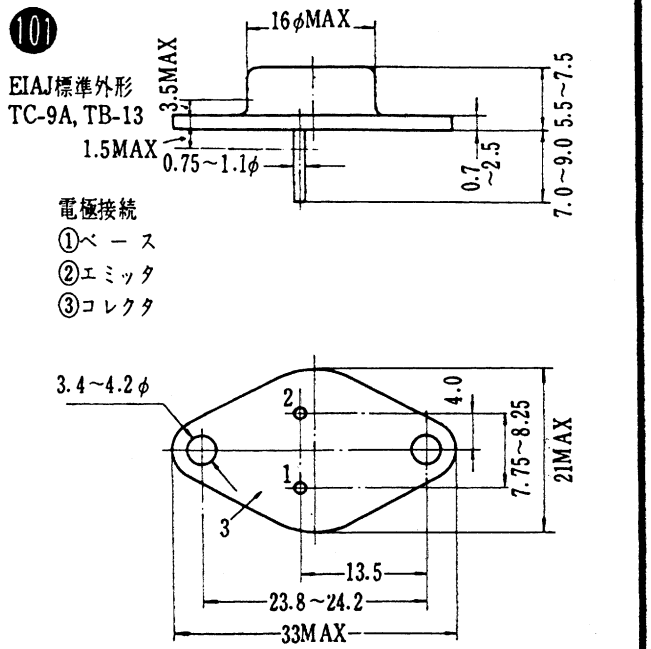
99



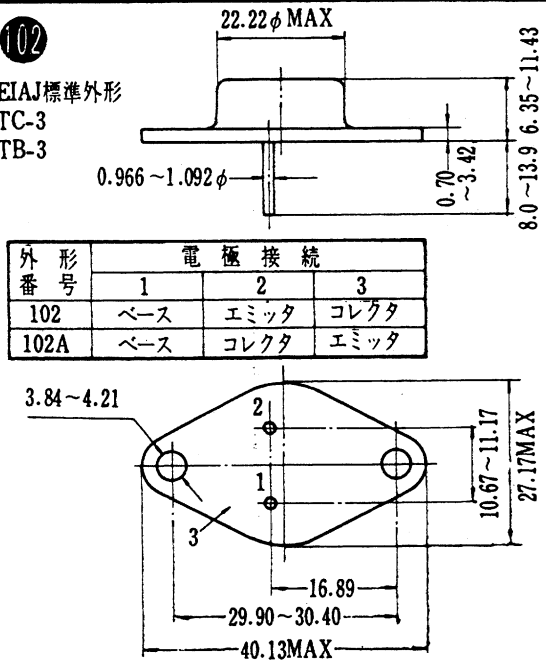
100



101



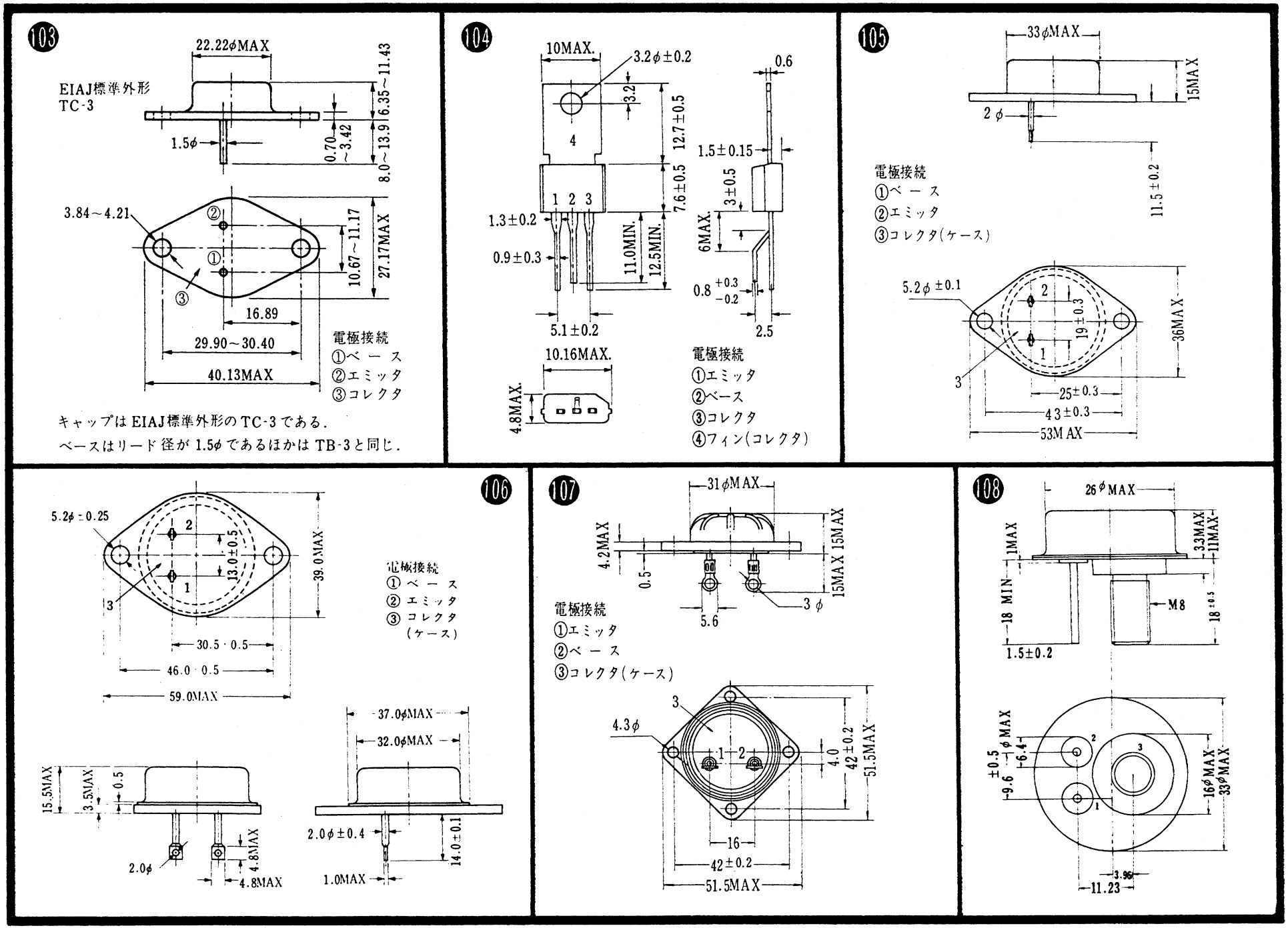
102



外形番号	電極接続 1	2	3
102	ベース	エミッタ	コレクタ
102A	ベース	コレクタ	エミッタ

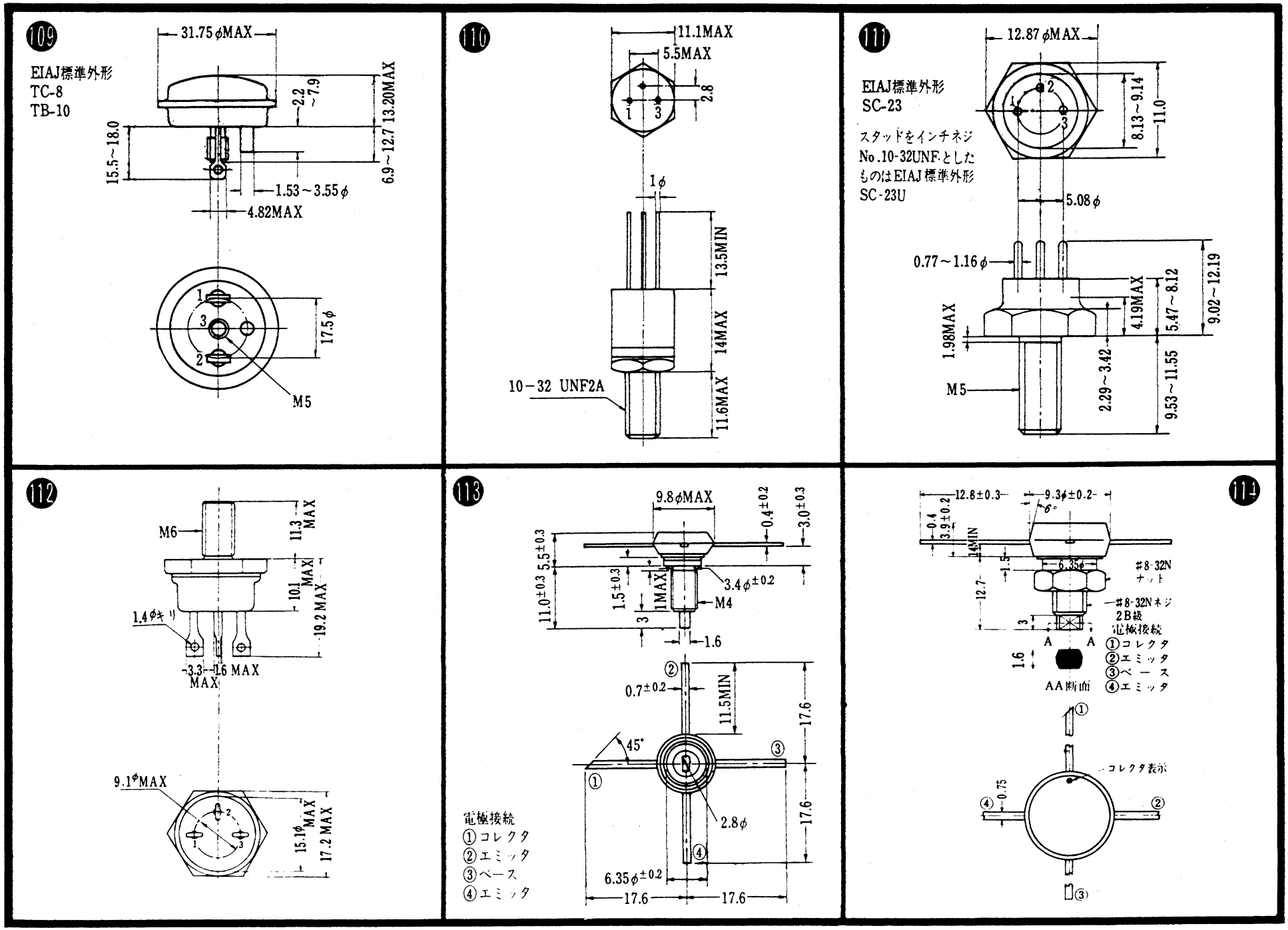
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

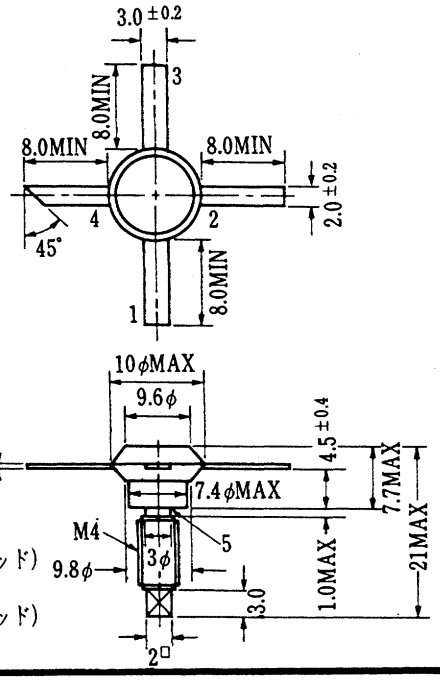
〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

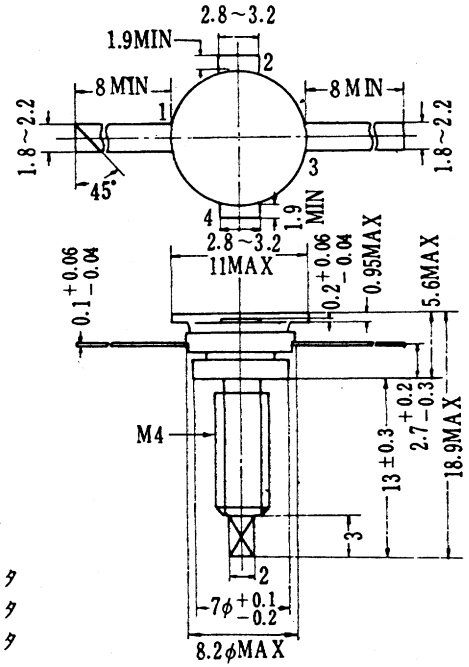
《寸法図単位：mm》

115



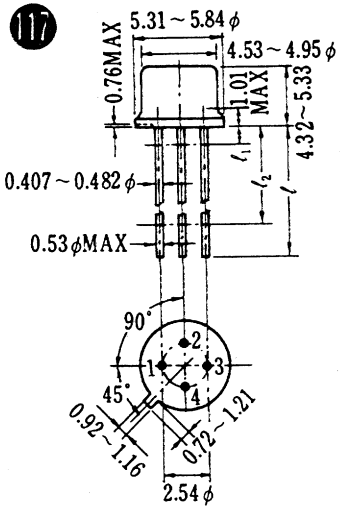
電極接続
①エミッタ(スタッド)
②コレクタ
③エミッタ(スタッド)
④ベース

116



電極接続
①ベース
②エミッタ
③コレクタ
④エミッタ

117

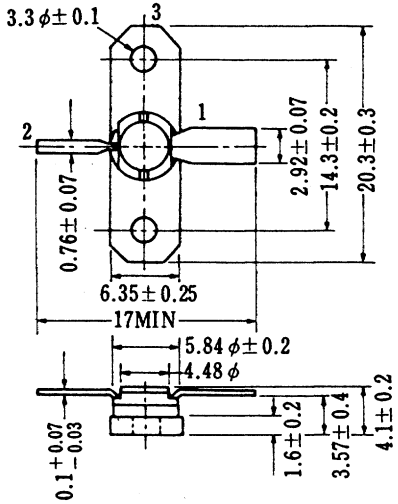


EIAJ標準外形
TC-7
TB-9A
TB-9B
TB-9C

電極接続
①ベース
②エミッタ
③コレクタ
④シールド

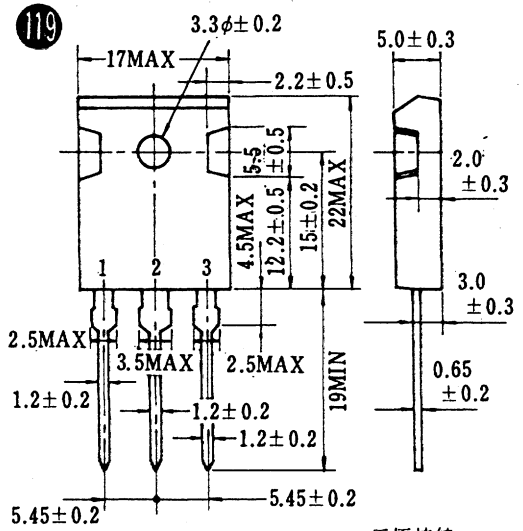
照合文字	A	B	C
ℓ	38.1MIN	19.0MIN	12.5MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4MIN	12.7MIN	6.35MIN

118



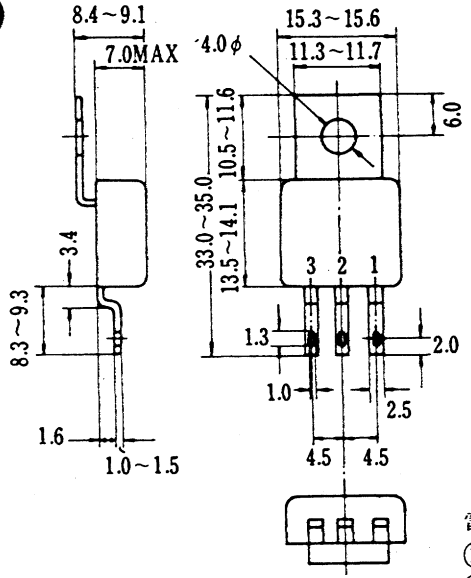
外形番号	電極接続		
	1	2	3
118A	ベース	コレクタ	エミッタ
118B	エミッタ	コレクタ	ベース

119



電極接続
1.ベース
2.コレクタ
3.エミッタ

120

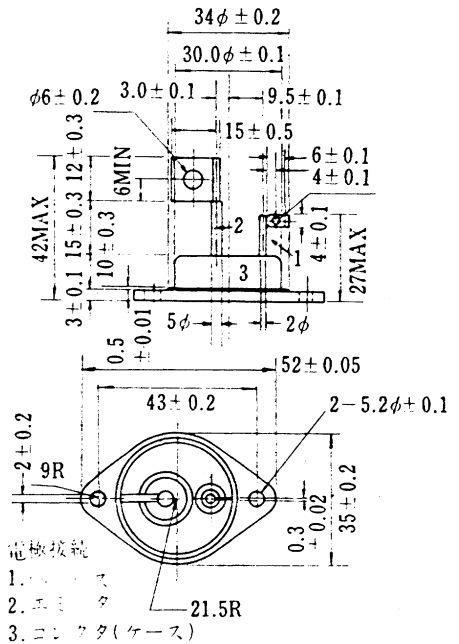


電極接続
①エミッタ
②ベース
③コレクタ

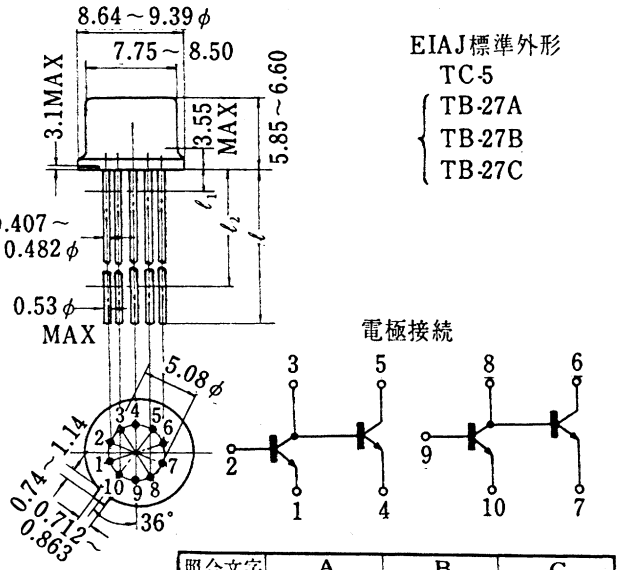
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉

121



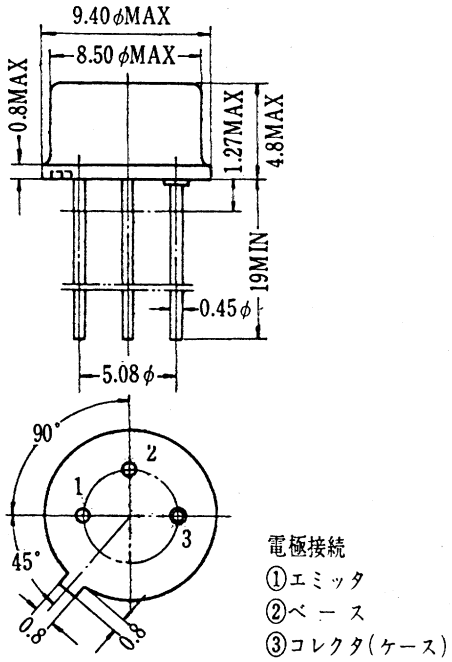
122



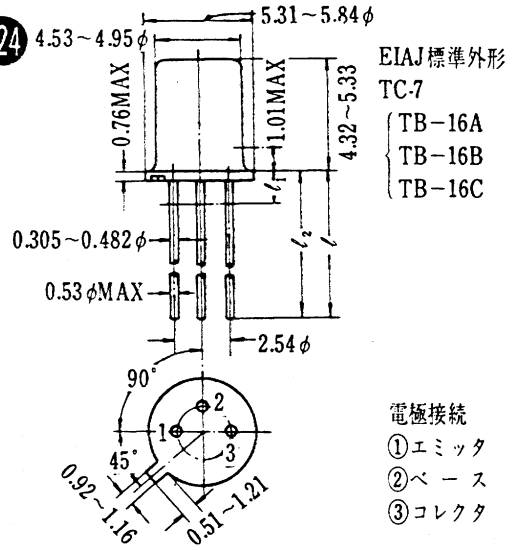
EIAJ標準外形
TC-5
TB-27A
TB-27B
TB-27C

照合文字	A	B	C
ℓ	38.1MIN	19.0MIN	12.5MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4MIN	12.7MIN	6.35MIN

123



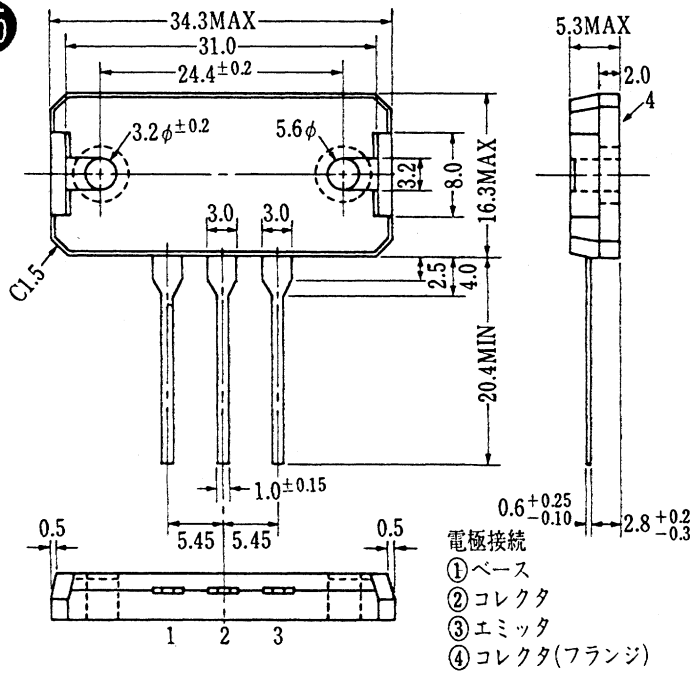
124



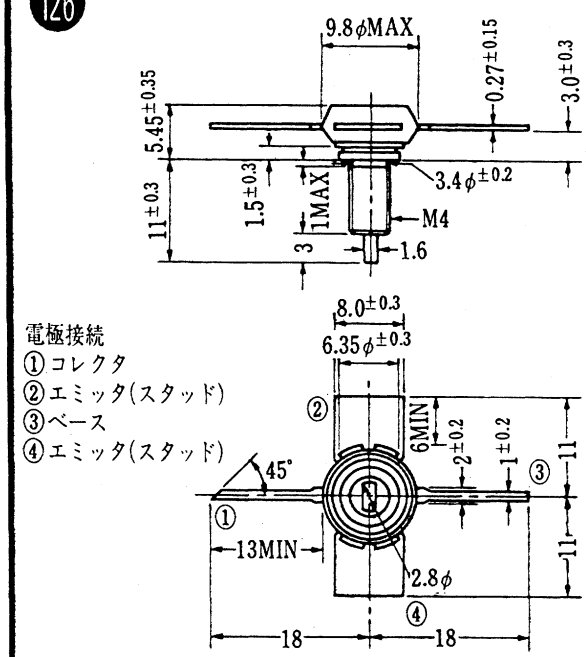
EIAJ標準外形
TC-7
TB−16A
TB−16B
TB−16C

照合文字	A	B	C
ℓ	38.1MIN	19.0MIN	12.5MIN
ℓ_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ_2	25.4MIN	12.7MIN	6.35MIN

125

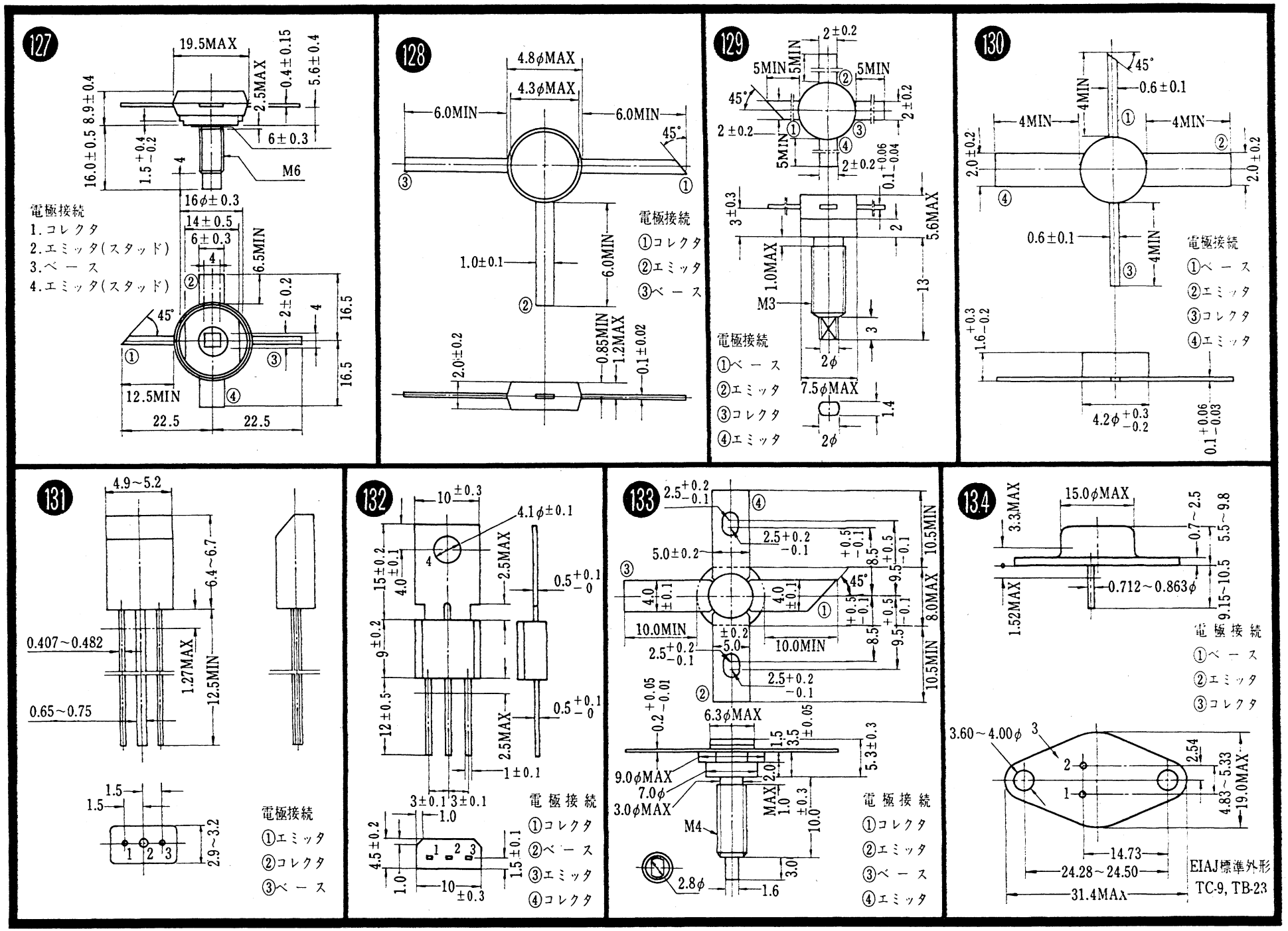


126



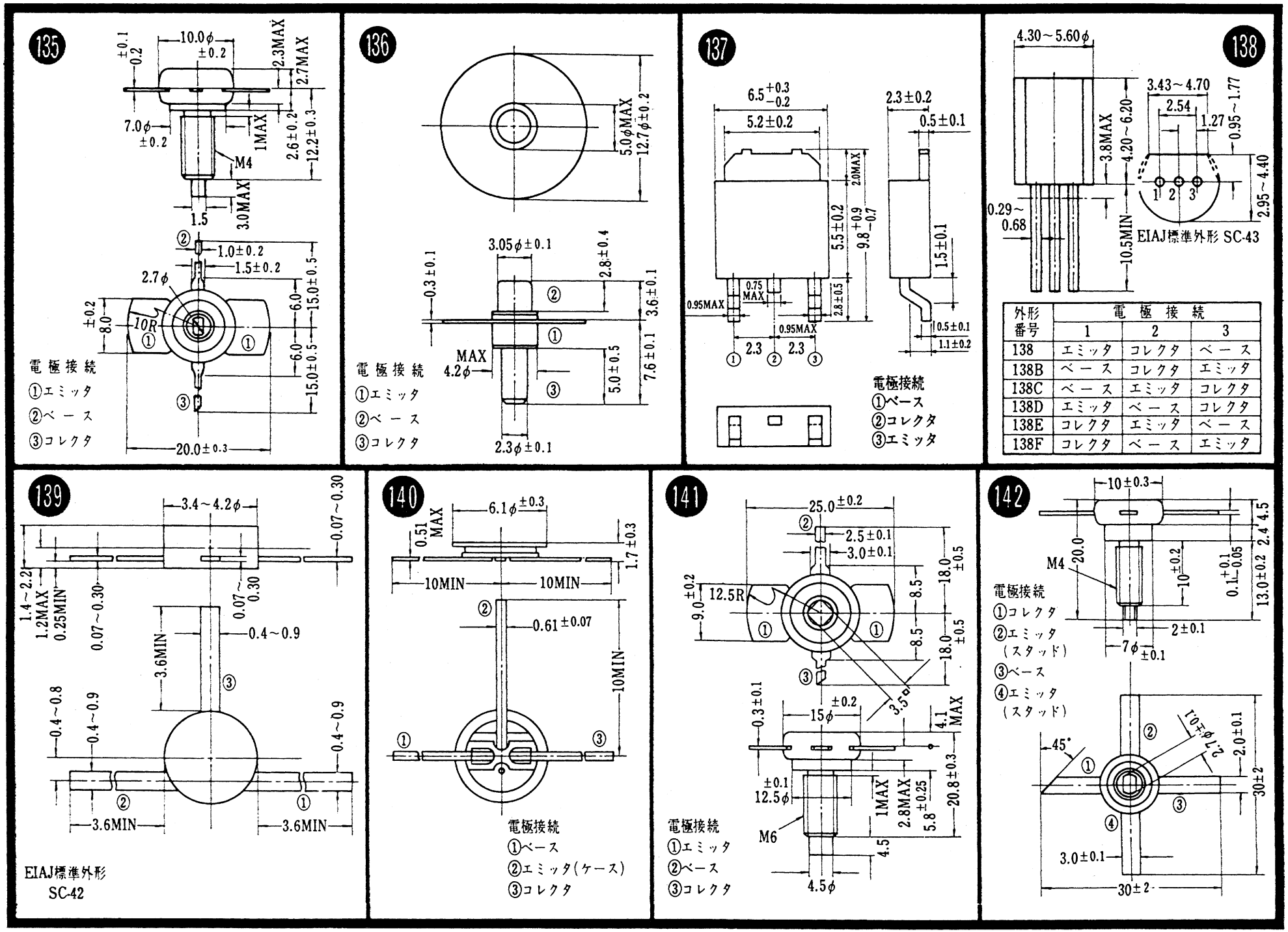
● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

《寸法図単位：mm》



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

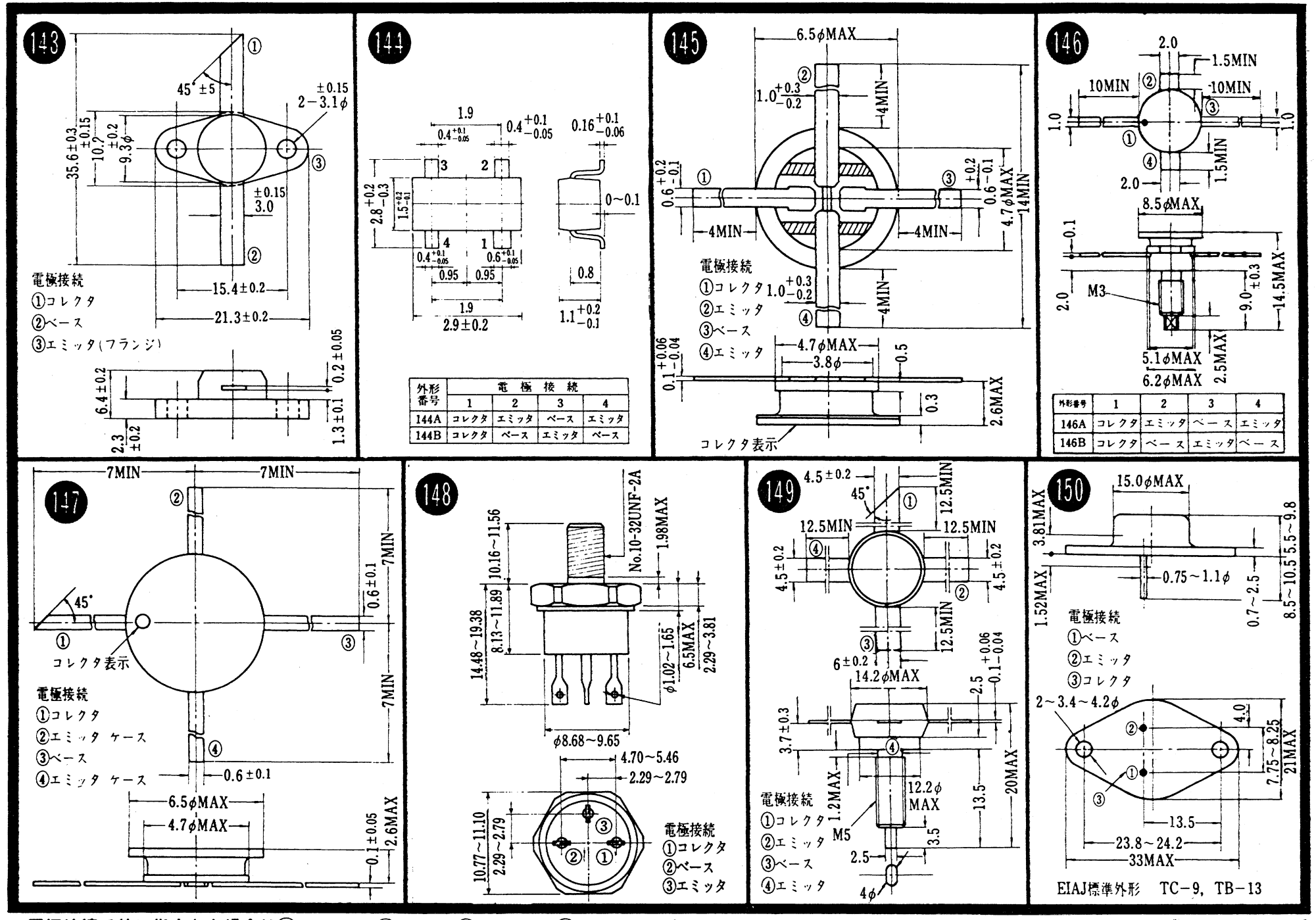
《寸法図単位：mm》



外形番号	電極接続 1	電極接続 2	電極接続 3
138	エミッタ	コレクタ	ベース
138B	ベース	コレクタ	エミッタ
138C	ベース	エミッタ	コレクタ
138D	エミッタ	ベース	コレクタ
138E	コレクタ	エミッタ	ベース
138F	コレクタ	ベース	エミッタ

●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉

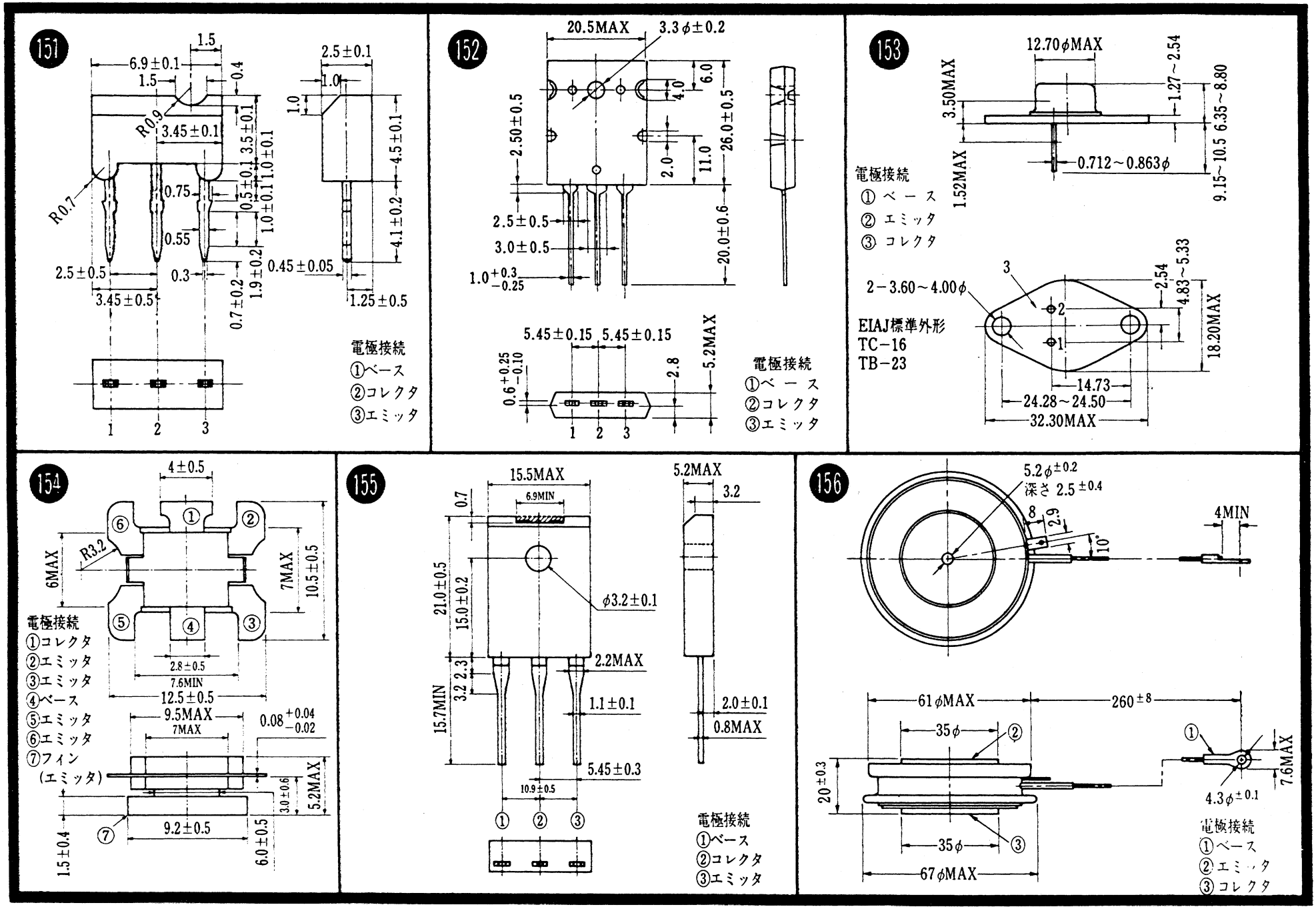


外形番号	電極接続			
	1	2	3	4
144A	コレクタ	エミッタ	ベース	エミッタ
144B	コレクタ	ベース	エミッタ	ベース

外形番号	1	2	3	4
146A	コレクタ	エミッタ	ベース	エミッタ
146B	コレクタ	ベース	エミッタ	ベース

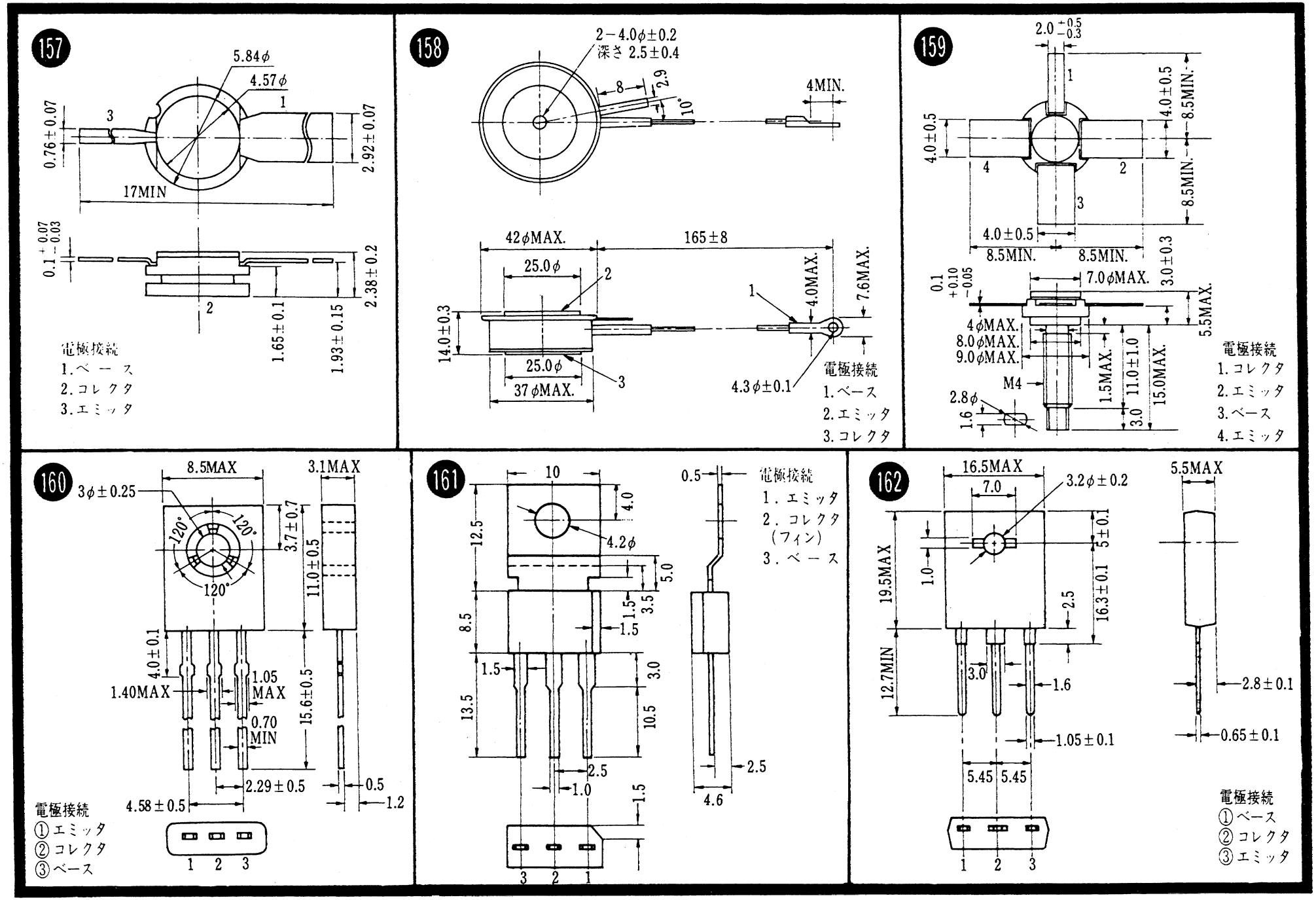
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



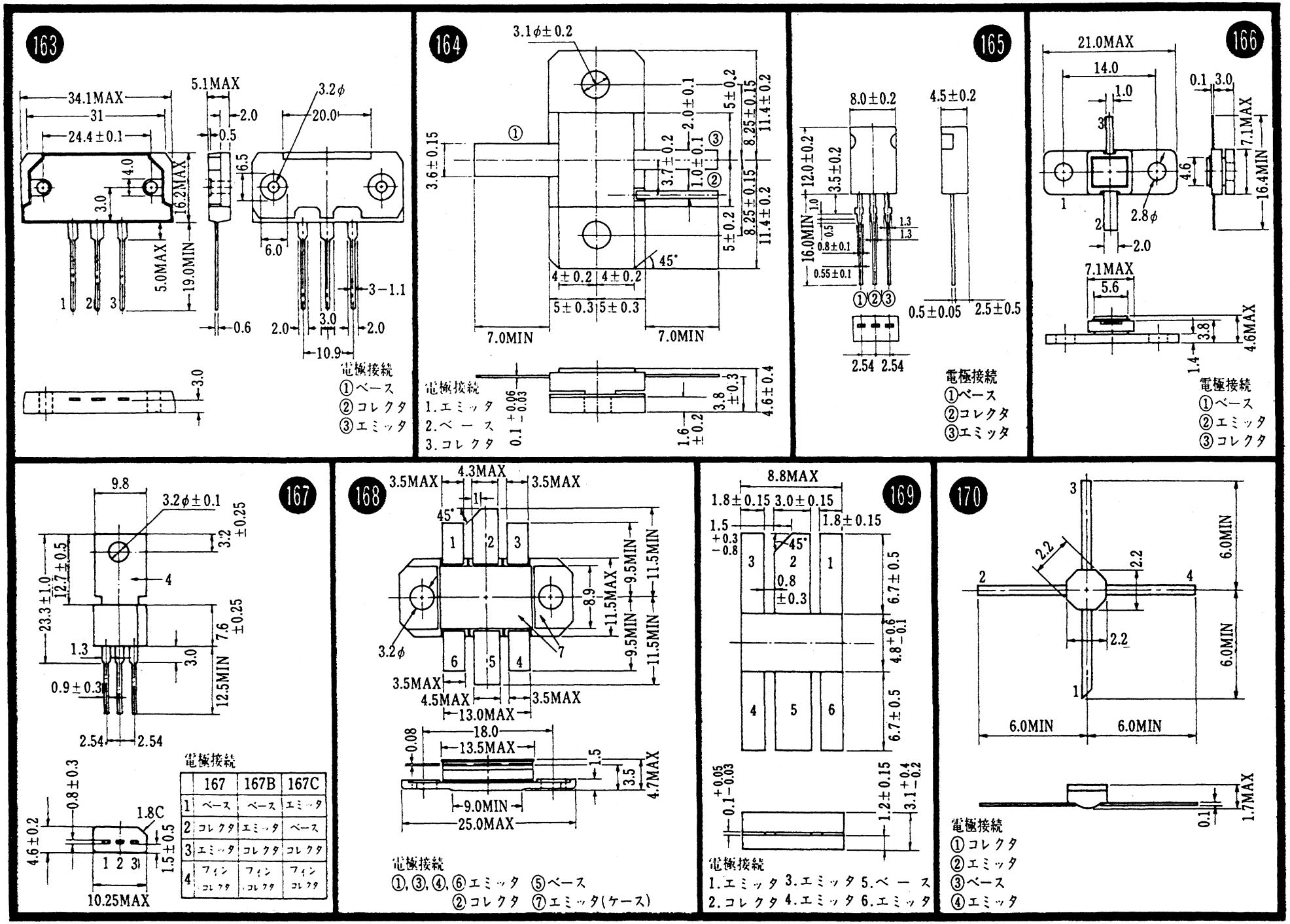
● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

《寸法図単位：mm》



● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

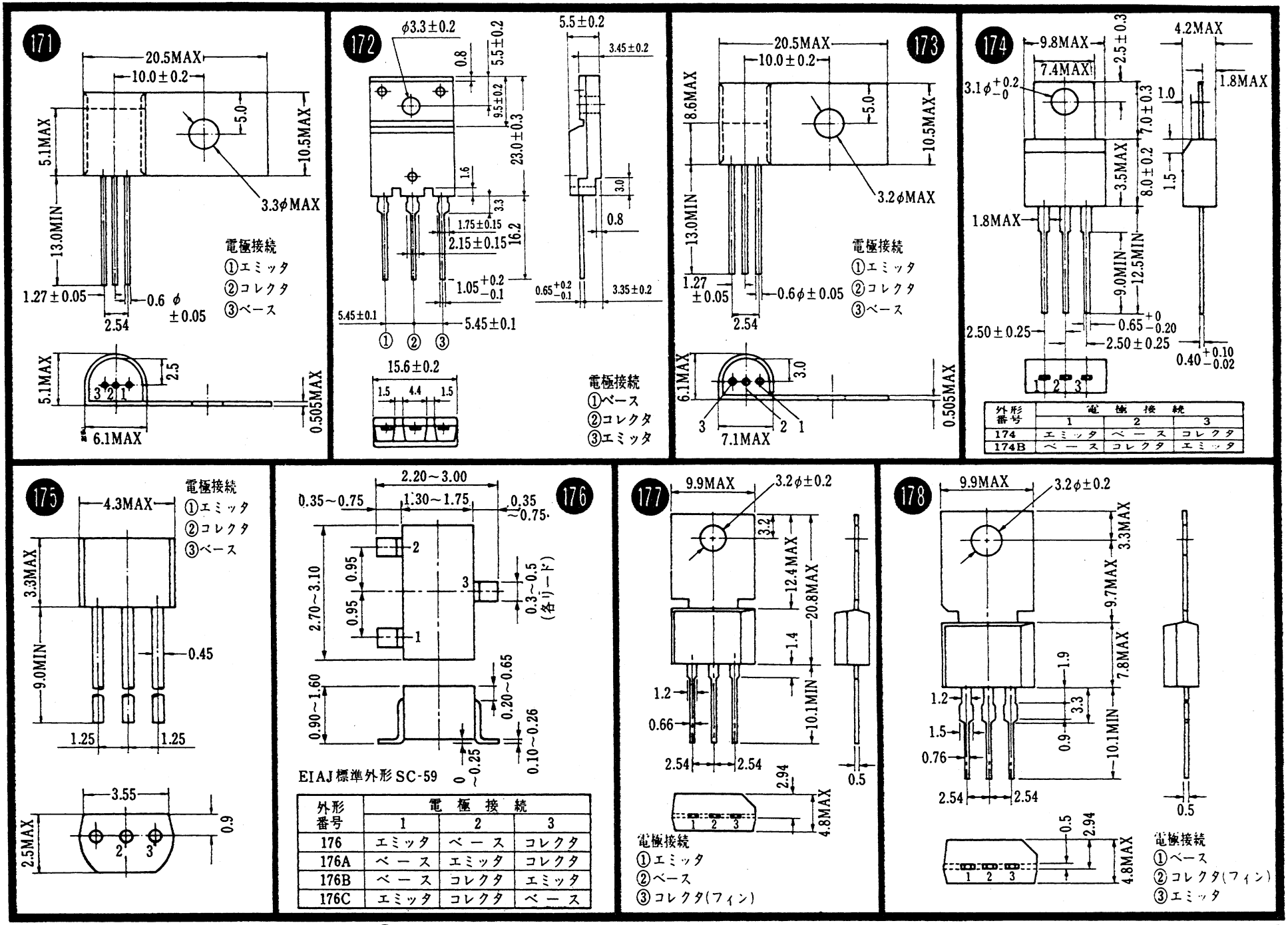
〈寸法図単位：mm〉



	167	167B	167C
1	ベース	ベース	エミッタ
2	コレクタ	エミッタ	ベース
3	エミッタ	コレクタ	コレクタ
4	フィン コレクタ	フィン コレクタ	フィン コレクタ

●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



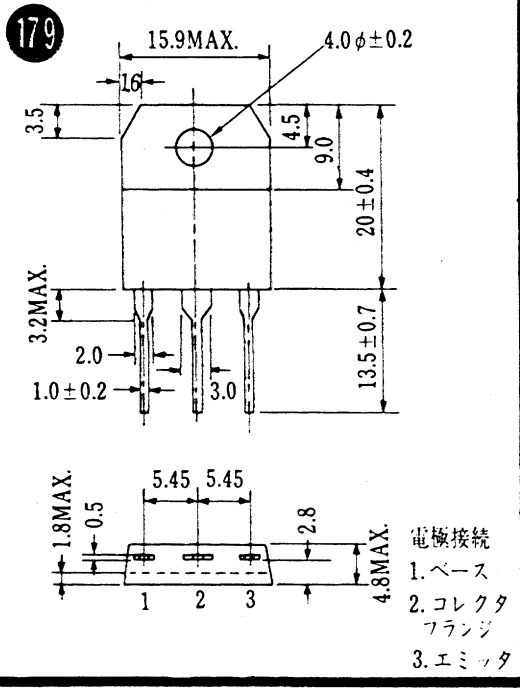
外形番号	電極接続 1	2	3
174	エミッタ	ベース	コレクタ
174B	ベース	コレクタ	エミッタ

外形番号	電極接続 1	2	3
176	エミッタ	ベース	コレクタ
176A	ベース	エミッタ	コレクタ
176B	ベース	コレクタ	エミッタ
176C	エミッタ	コレクタ	ベース

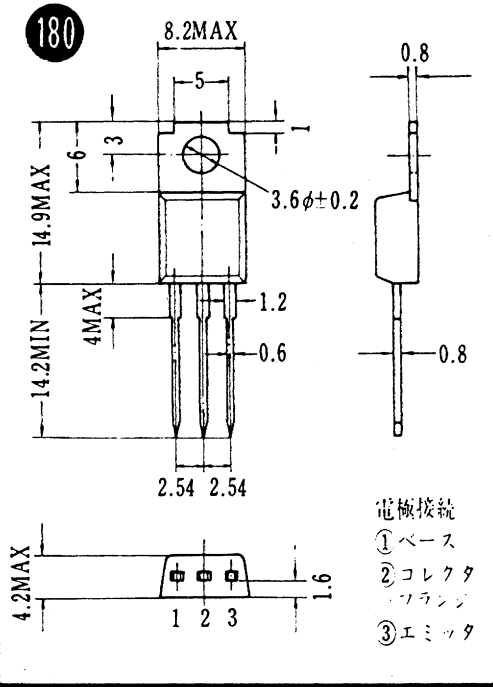
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉

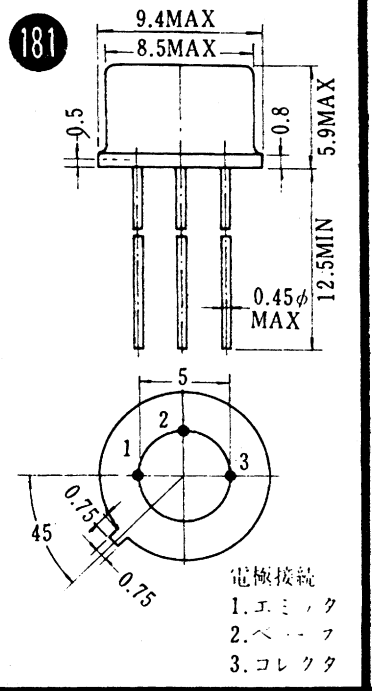
179



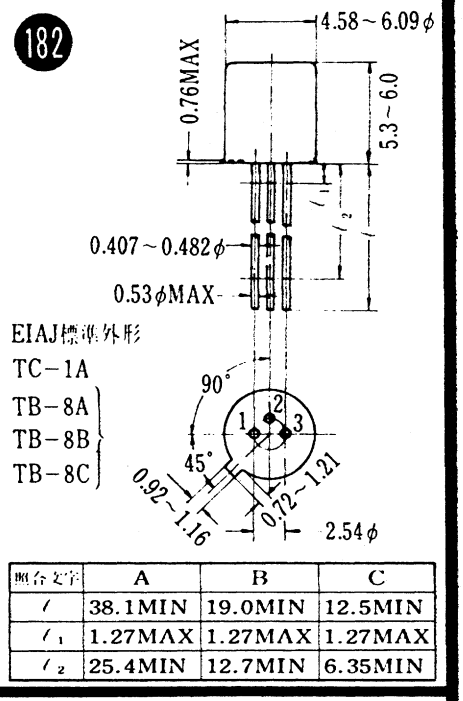
180



181

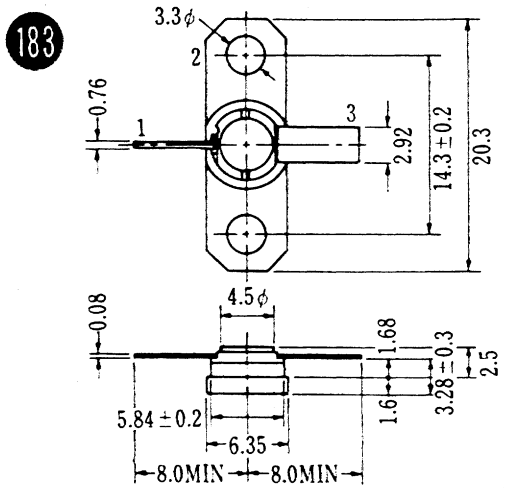


182



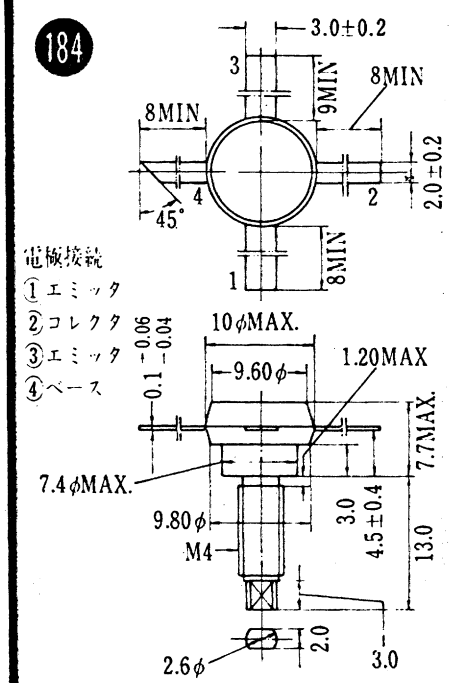
照合文字	A	B	C
l	38.1MIN	19.0MIN	12.5MIN
l_1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
l_2	25.4MIN	12.7MIN	6.35MIN

183

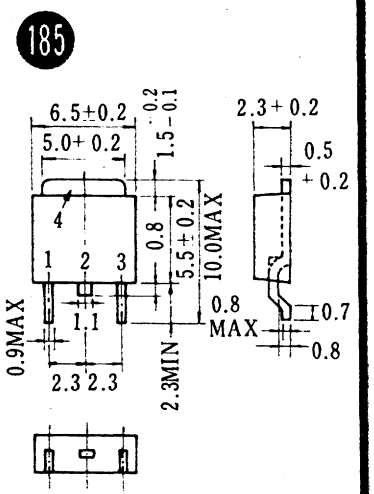


外形番号	電極接続		
	1	2	3
183A	コレクタ	エミッタ	ベース
183B	コレクタ	ベース	エミッタ
183C	エミッタ	コレクタ	ベース

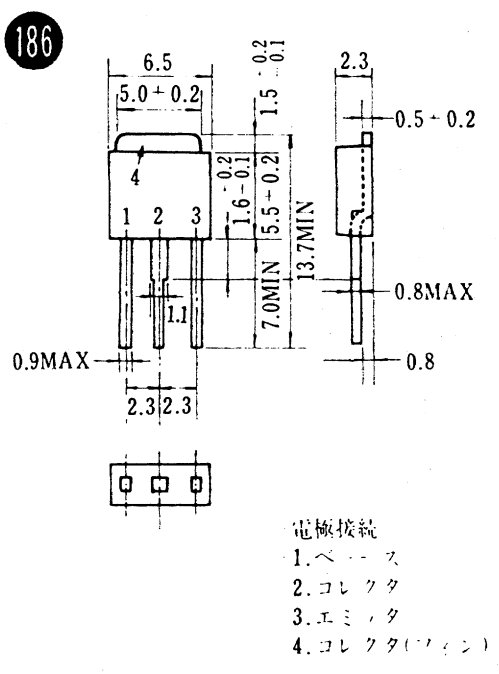
184



185

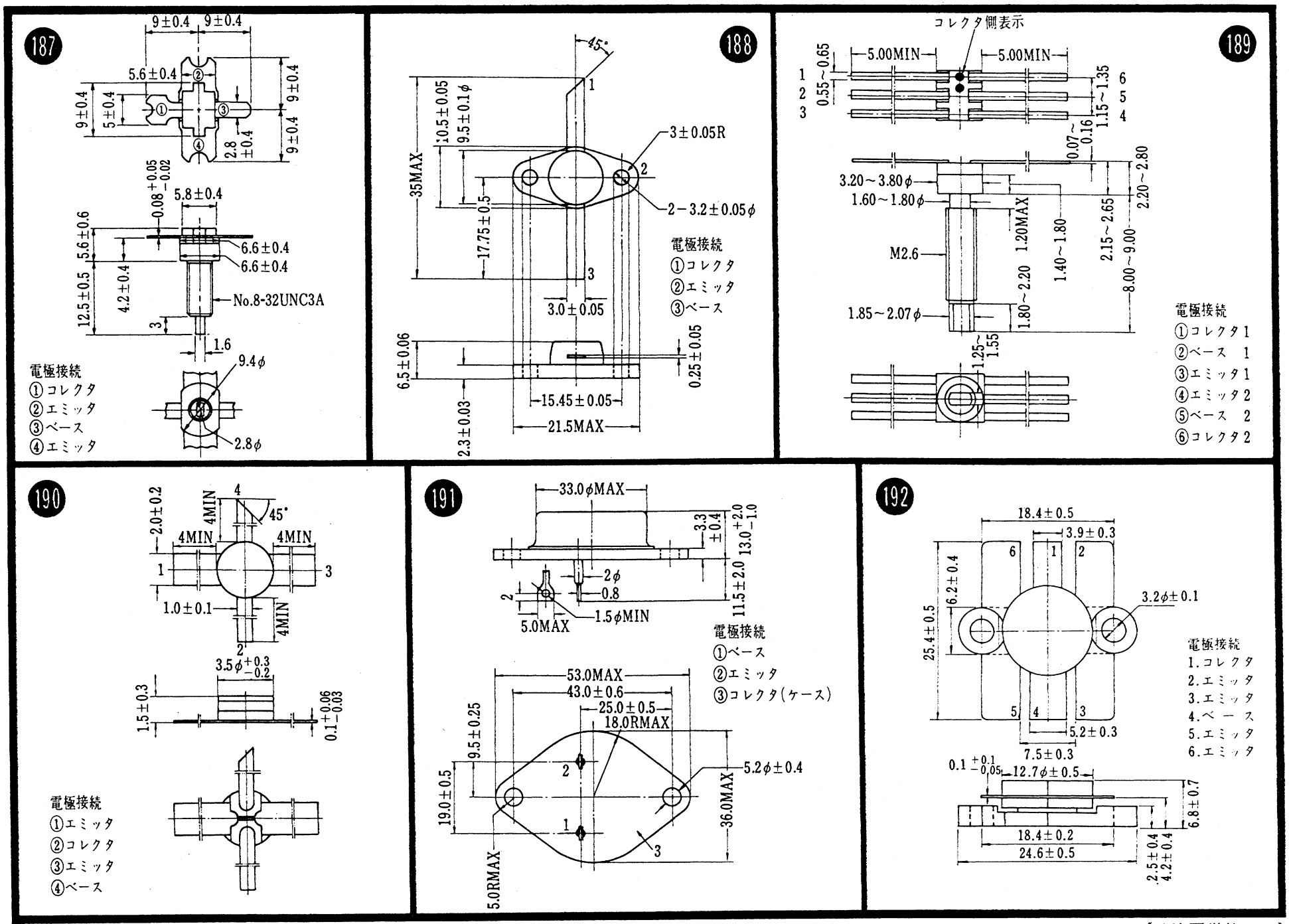


186



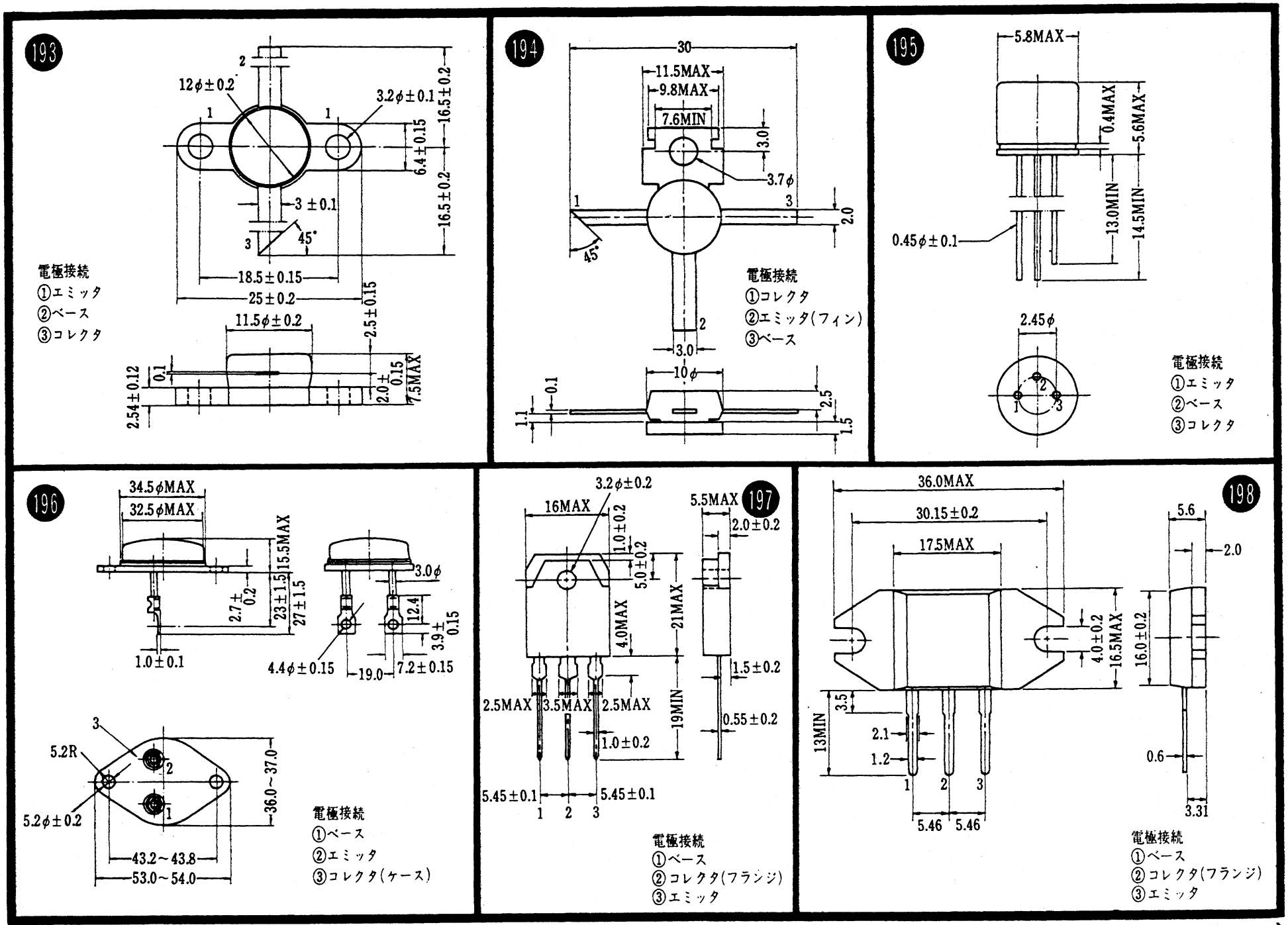
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

《寸法図単位：mm》



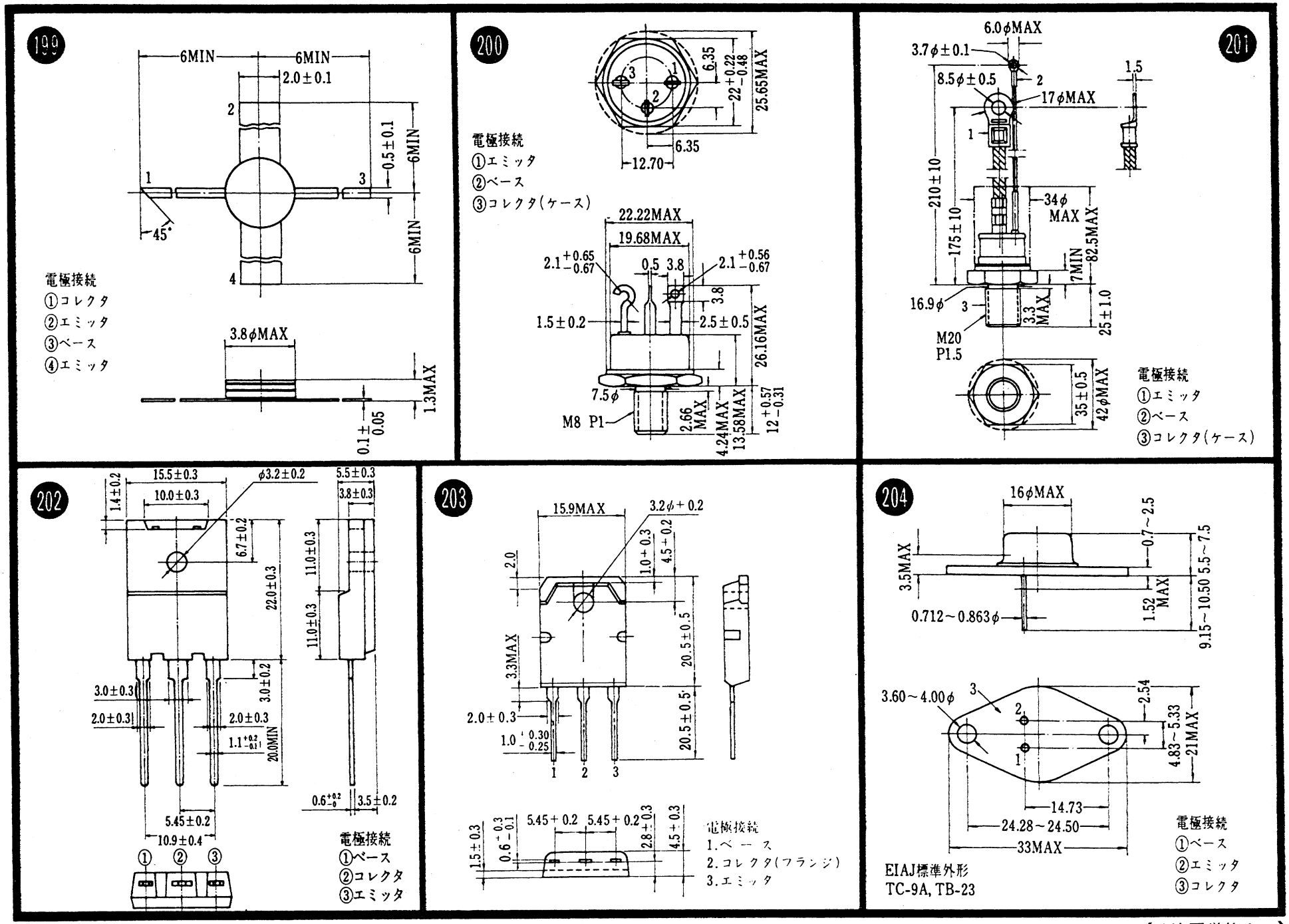
● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

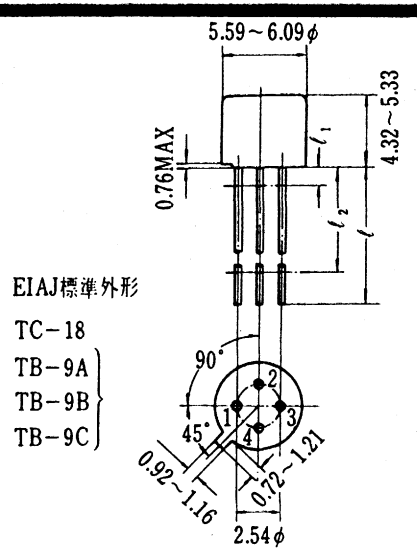
〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

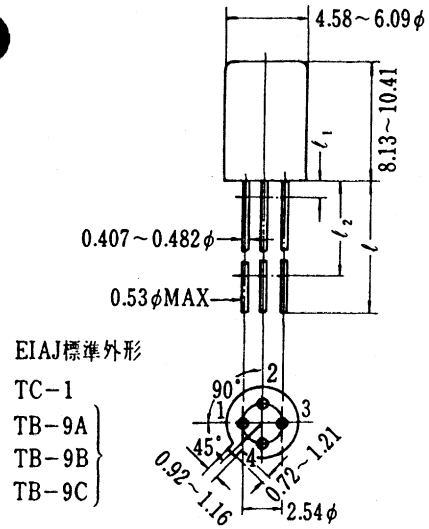
〈寸法図単位：mm〉

205



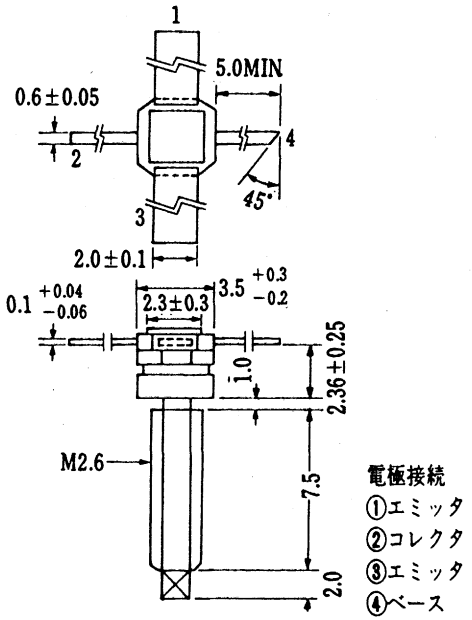
照合文字	A	B	C
ℓ	38.1MIN	19.0MIN	12.5MIN
ℓ1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ2	25.4MIN	12.7MIN	6.35MIN

206

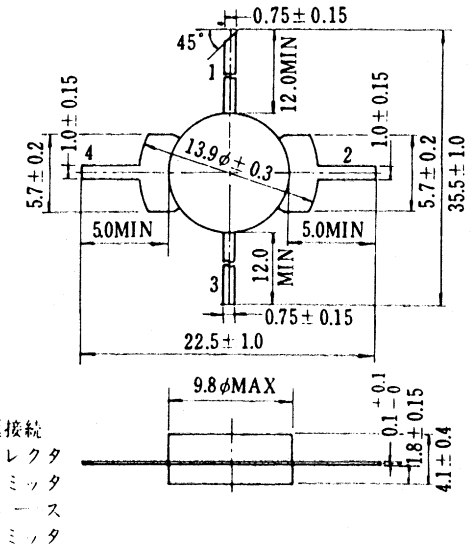


照合文字	A	B	C
ℓ	38.1MIN	19.0MIN	12.5MIN
ℓ1	1.27MAX	1.27MAX	1.27MAX
ℓ2	25.4MIN	12.7MIN	6.35MIN

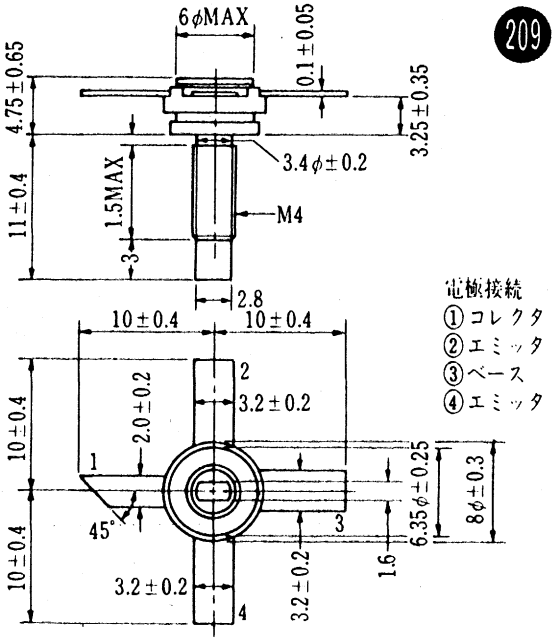
207



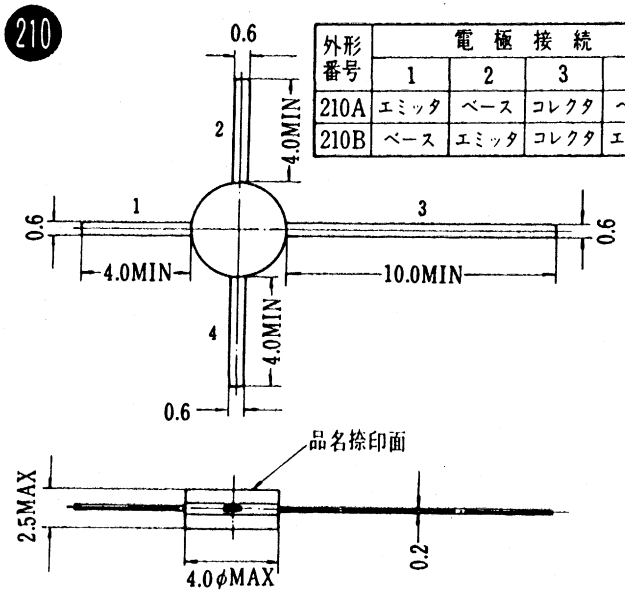
208



209



210

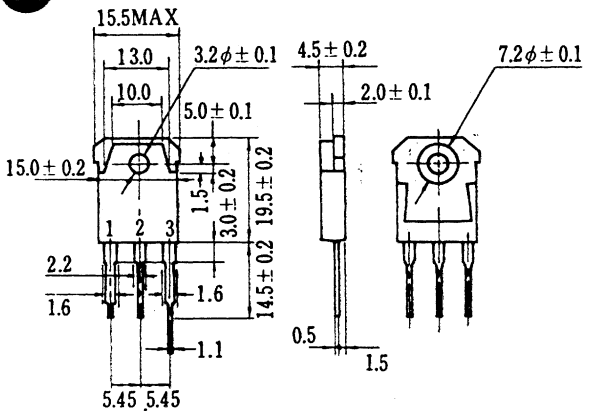


外形番号	電極接続 1	2	3	4
210A	エミッタ	ベース	コレクタ	ベース
210B	ベース	エミッタ	コレクタ	エミッタ

● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

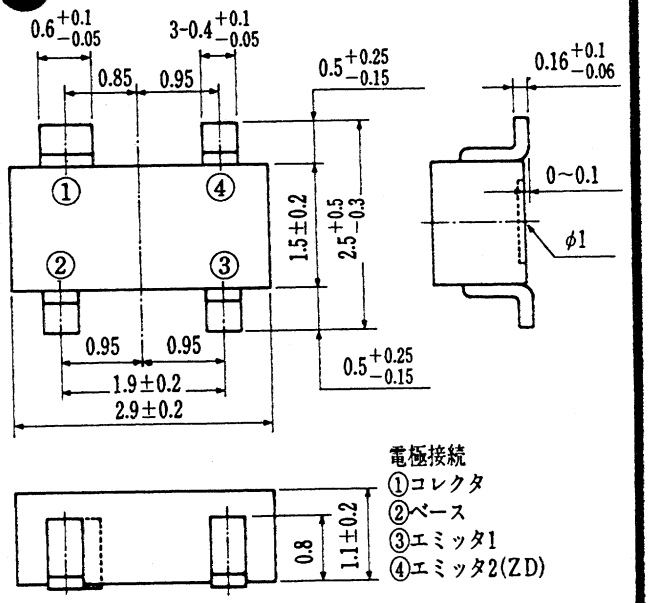
《寸法図単位：mm》

211



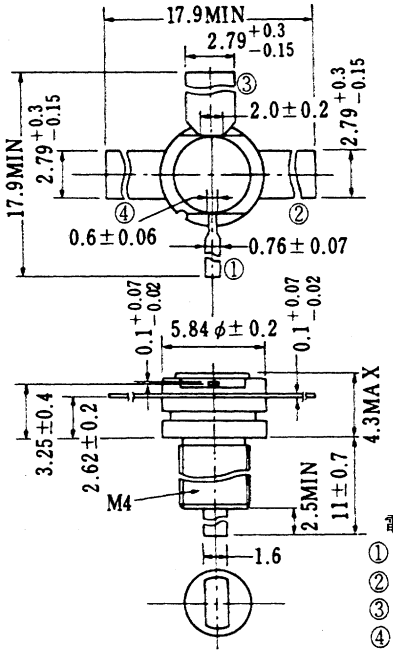
電極接続
①ベース
②コレクタ(フランジ)
③エミッタ

212



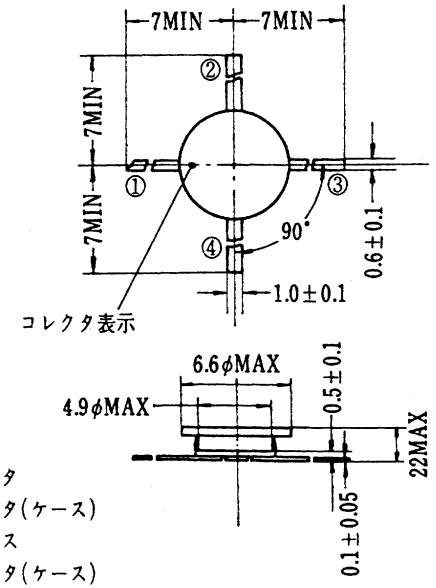
電極接続
①コレクタ
②ベース
③エミッタ1
④エミッタ2(ZD)

213



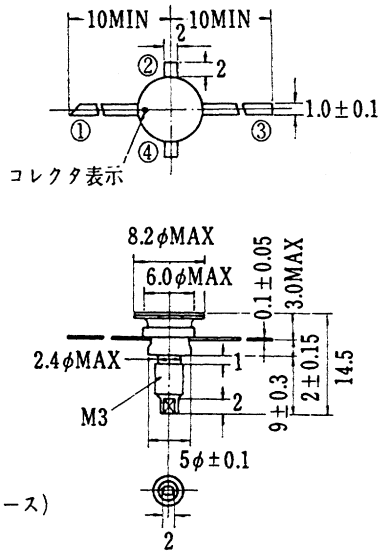
電極接続
①コレクタ
②エミッタ
③ベース
④エミッタ

214



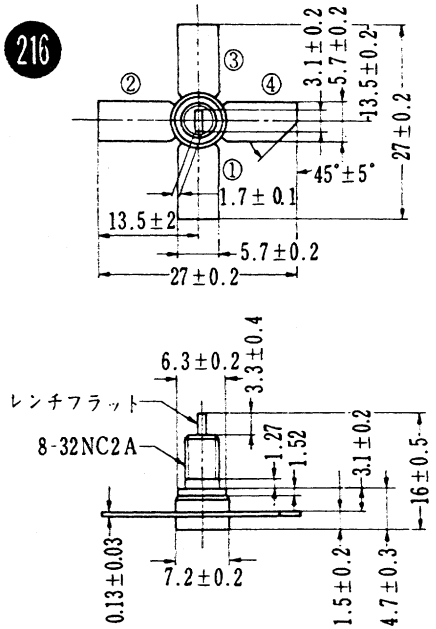
電極接続
①コレクタ
②エミッタ(ケース)
③ベース
④エミッタ(ケース)

215



電極接続
①コレクタ
②エミッタ(ケース)
③ベース
④エミッタ(ケース)

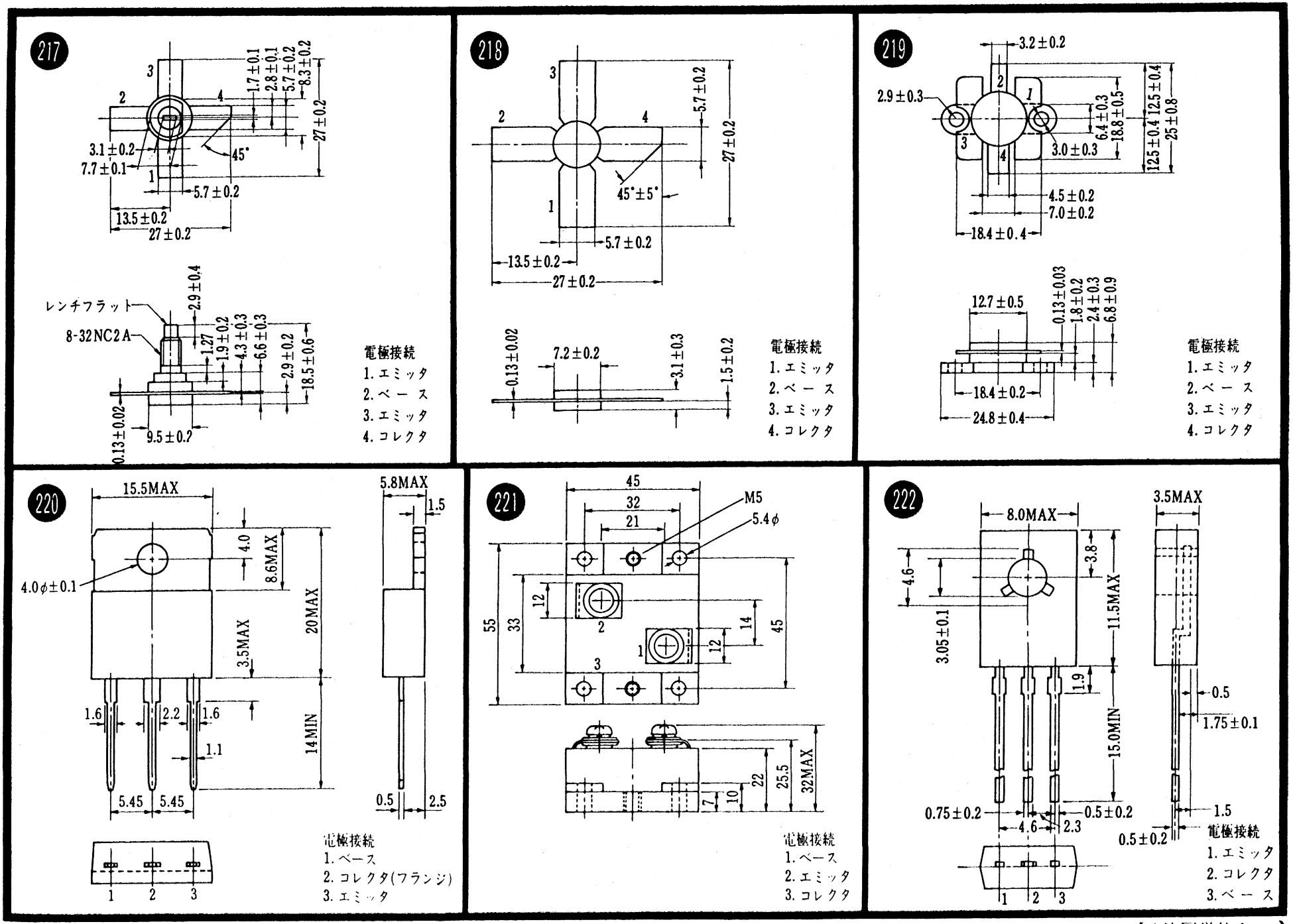
216



電極接続
①エミッタ
②ベース
③エミッタ
④コレクタ

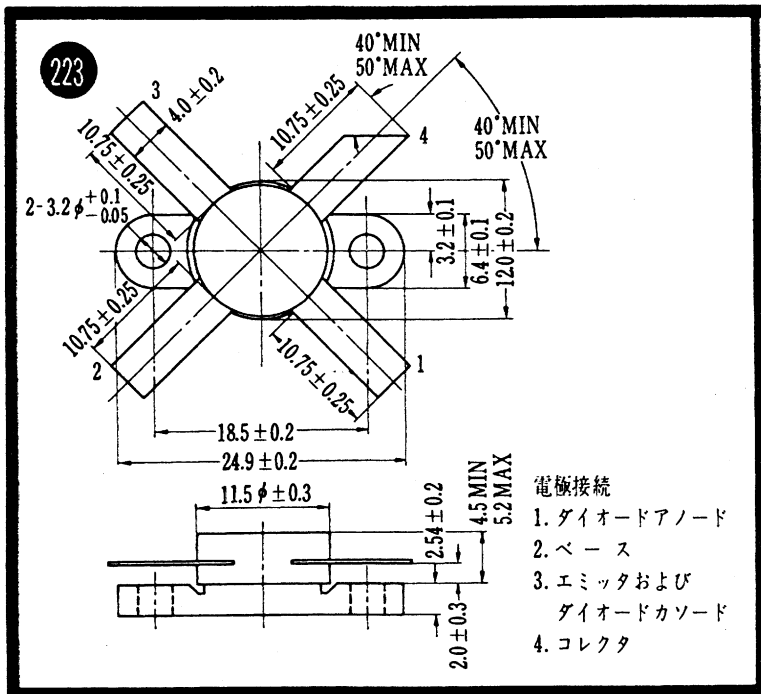
● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

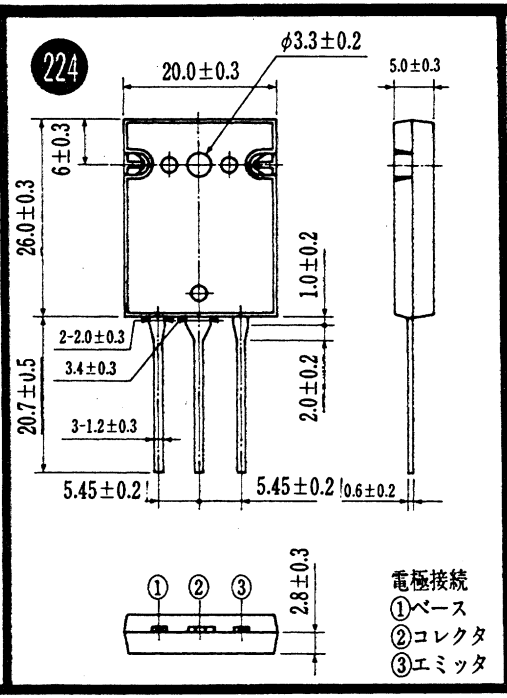
〈寸法図単位：mm〉

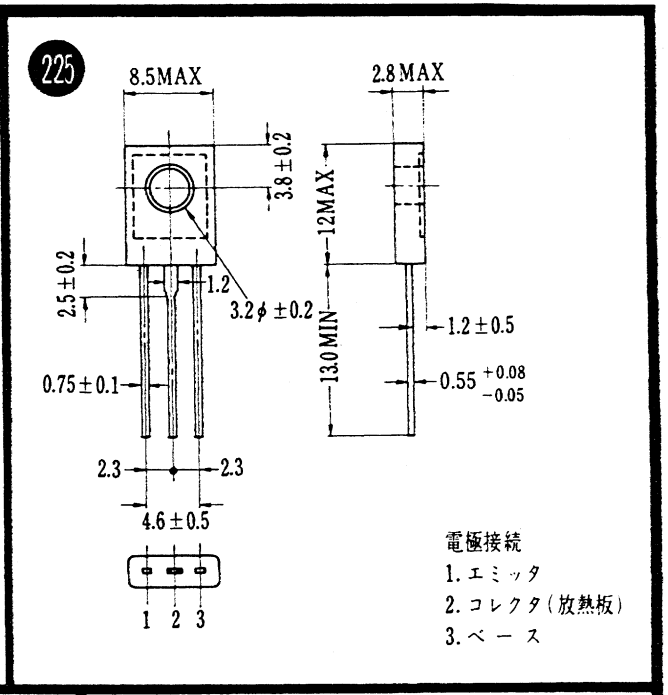


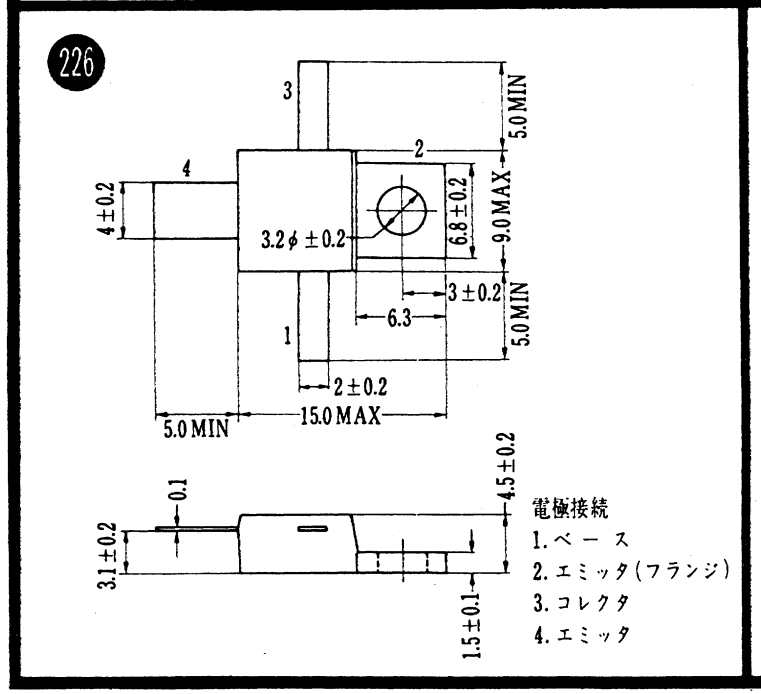
● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

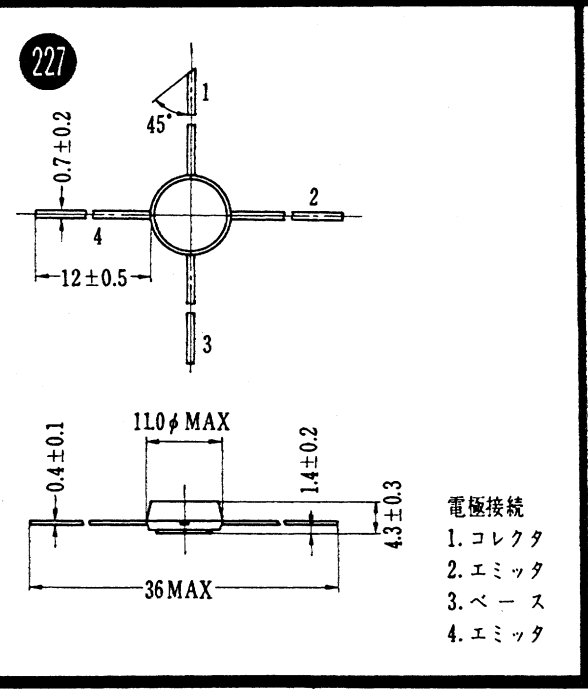
〈寸法図単位：mm〉

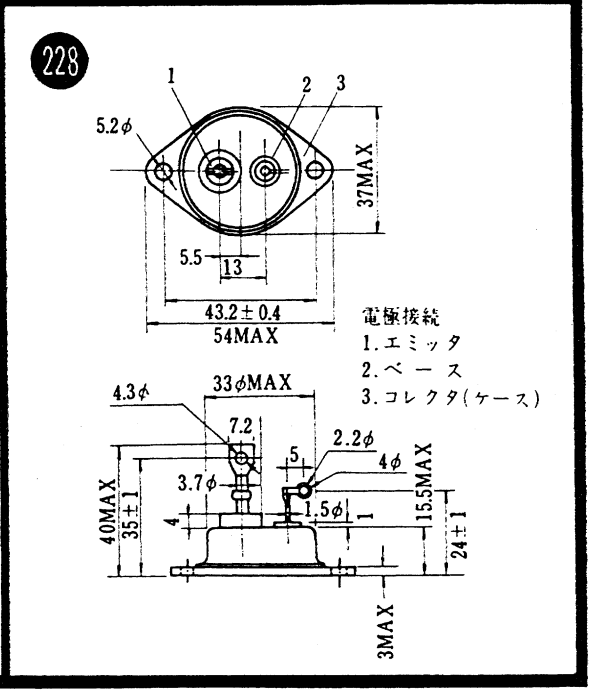






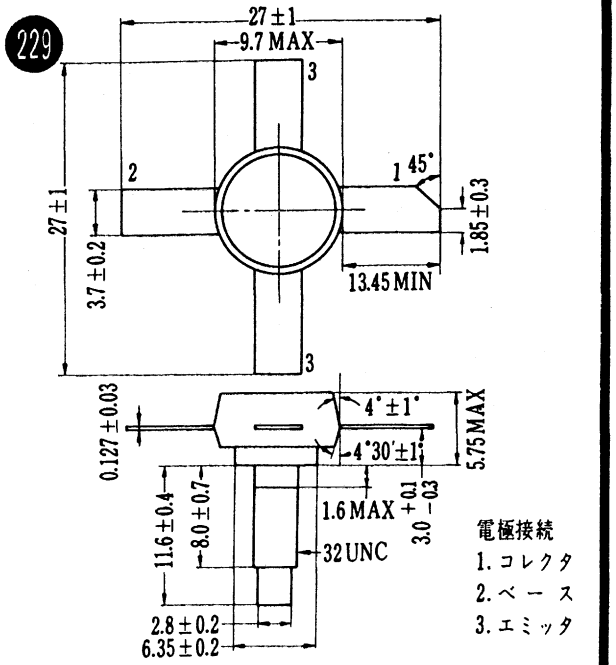


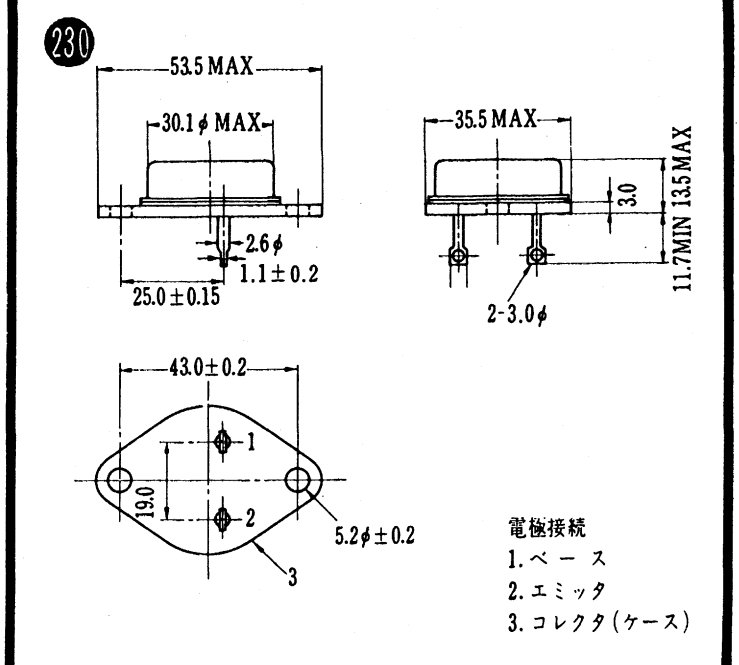


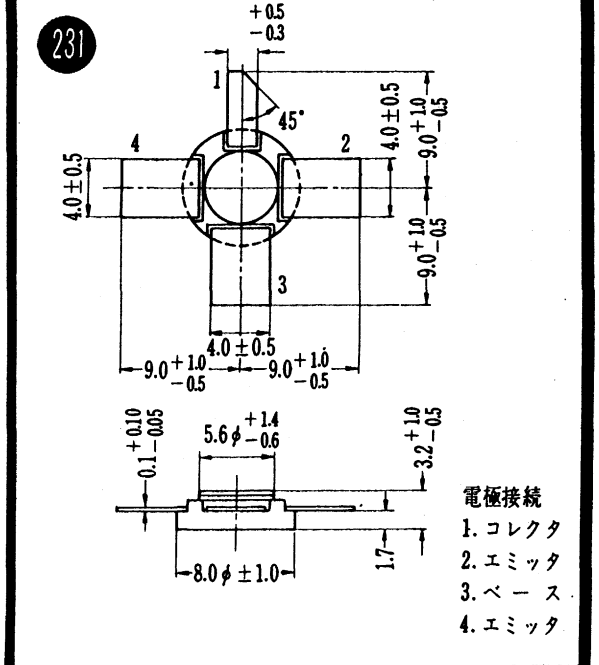


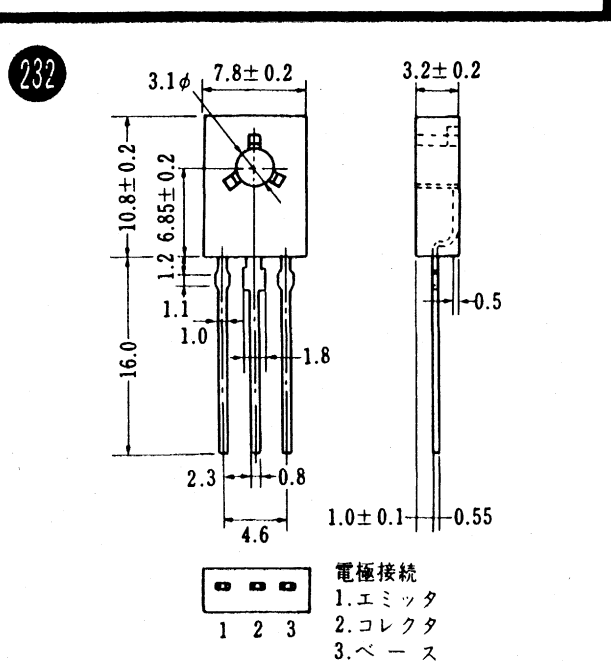
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

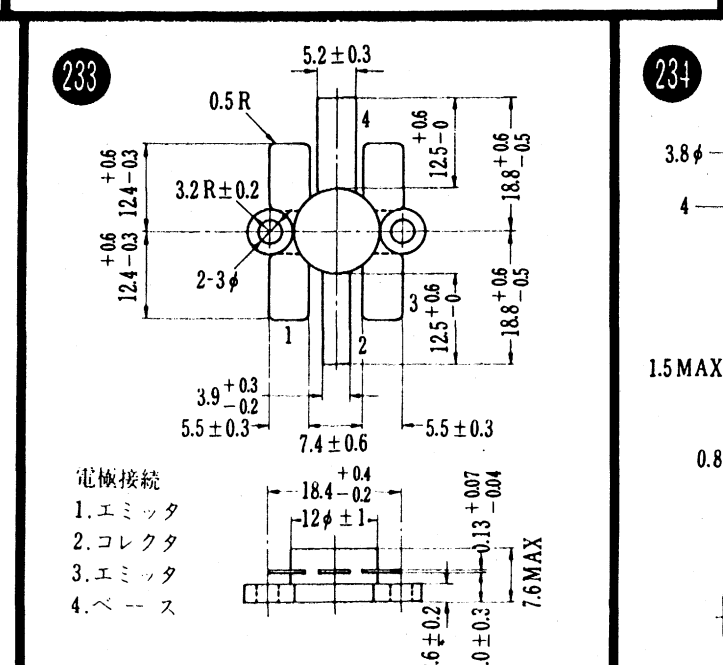
〈寸法図単位：mm〉

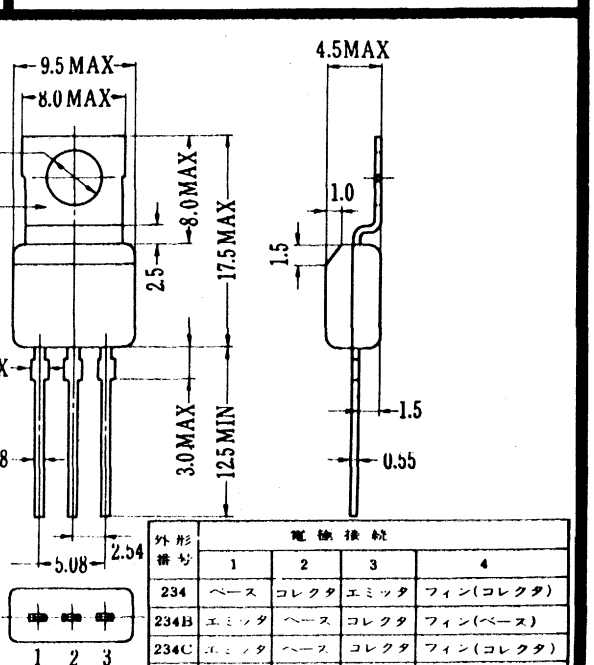










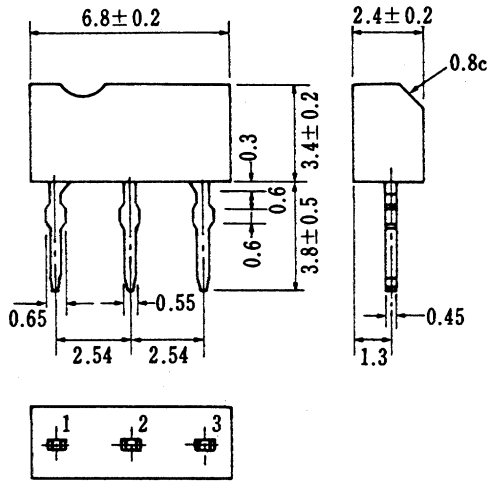


外形番号	電極接続 1	2	3	4
234	ベース	コレクタ	エミッタ	フィン(コレクタ)
234B	エミッタ	ベース	コレクタ	フィン(ベース)
234C	エミッタ	ベース	コレクタ	フィン(コレクタ)
234D	コレクタ	ベース	エミッタ	フィン(コレクタ)

●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ，②ベース，③コレクタ，④シールドです

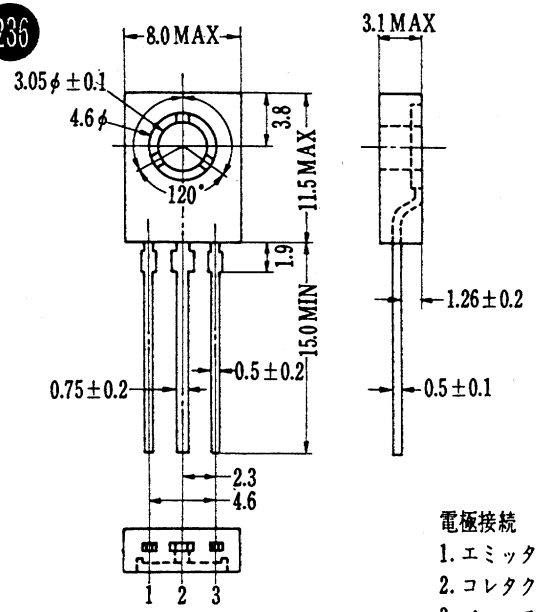
《寸法図単位：mm》

235



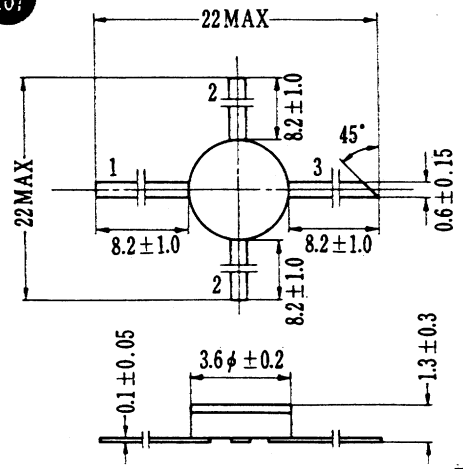
電極接続
1.エミッタ
2.コレクタ
3.ベ ー ス

236



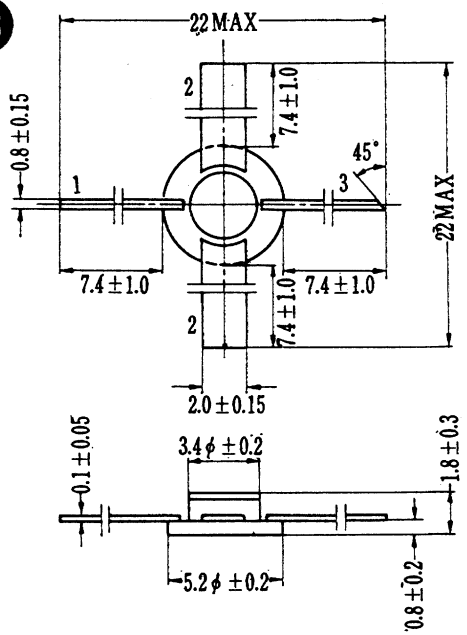
電極接続
1.エミッタ
2.コレクタ
3.ベ ー ス

237



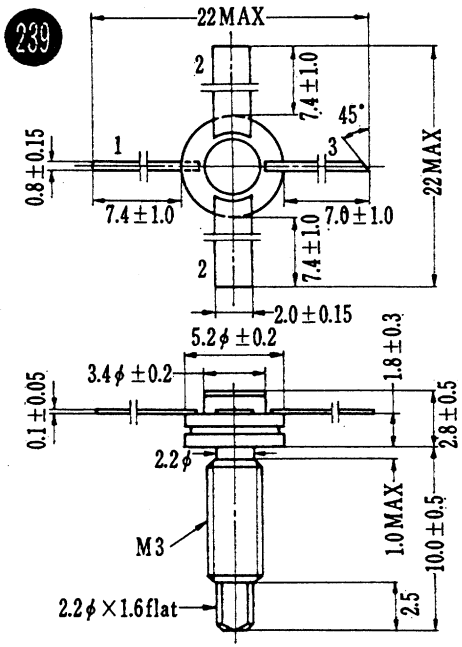
電極接続
1.ベ ー ス
2.エミッタ
3.コレクタ

238



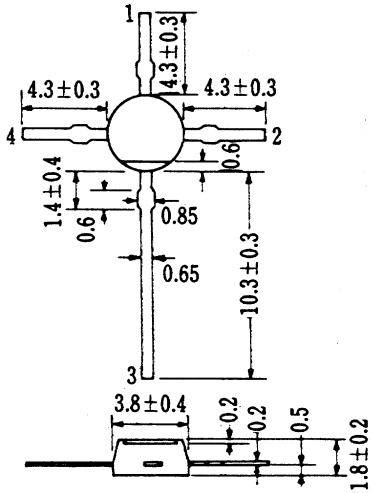
電極接続
1.ベ ー ス
2.エミッタ
3.コレクタ

239



電極接続
1.ベ ー ス
2.エミッタ
3.コレクタ

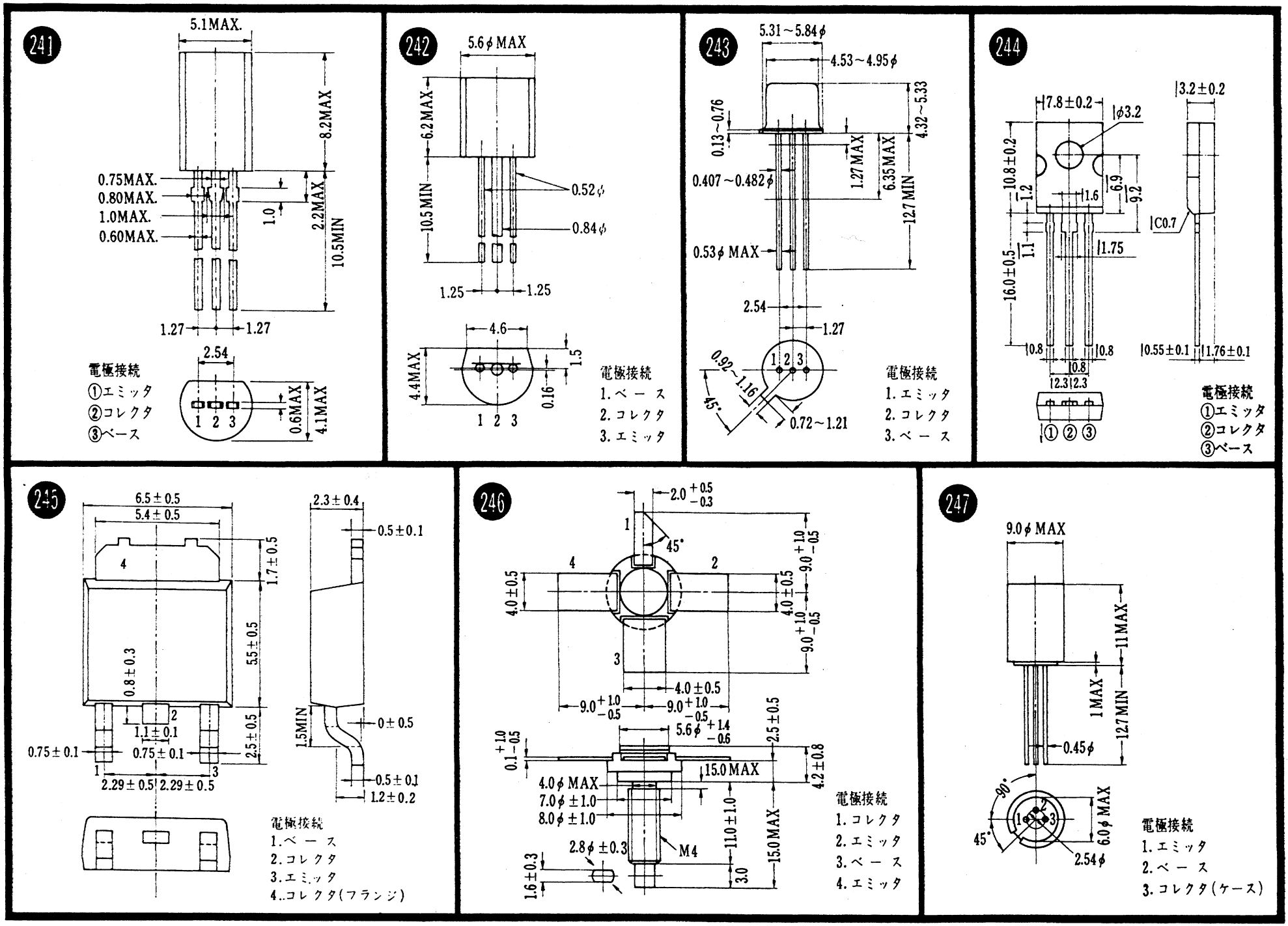
240



外形番号	電極接続			
	1	2	3	4
240A	エミッタ	ベース	コレクタ	ベース
240B	ベース	N.C.	エミッタ	コレクタ
240C	ベース	エミッタ	コレクタ	エミッタ

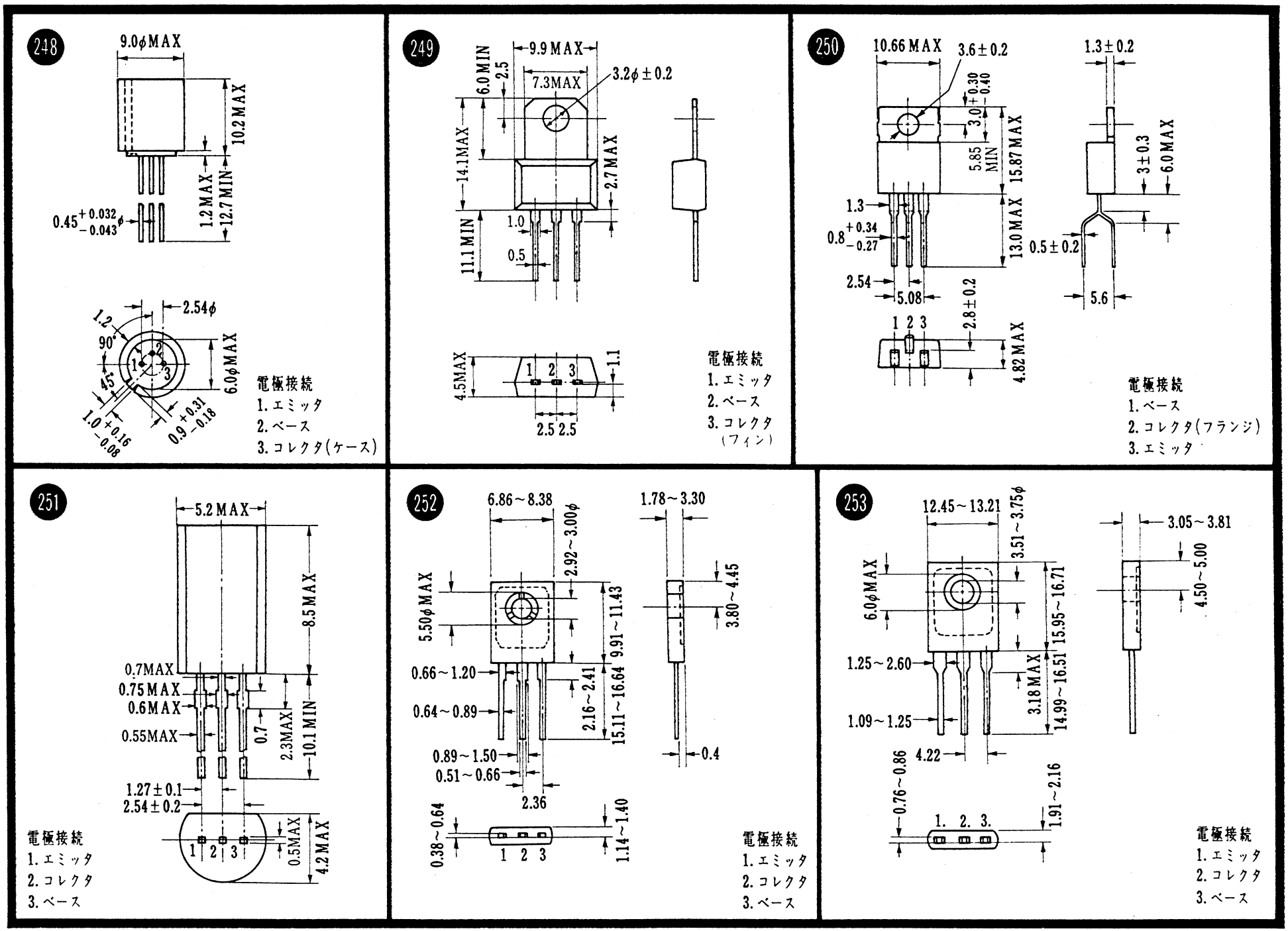
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ，②ベース，③コレクタ，④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



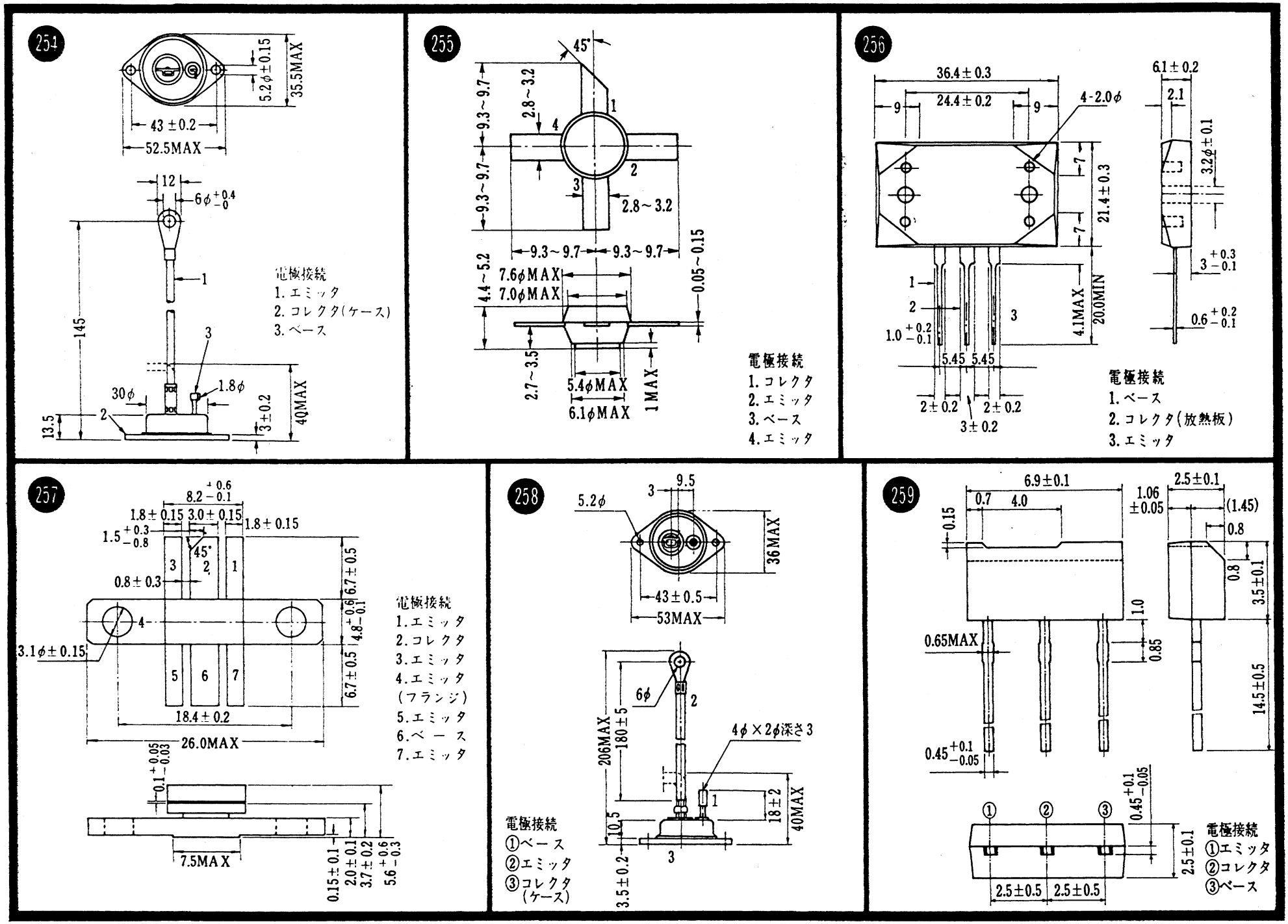
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



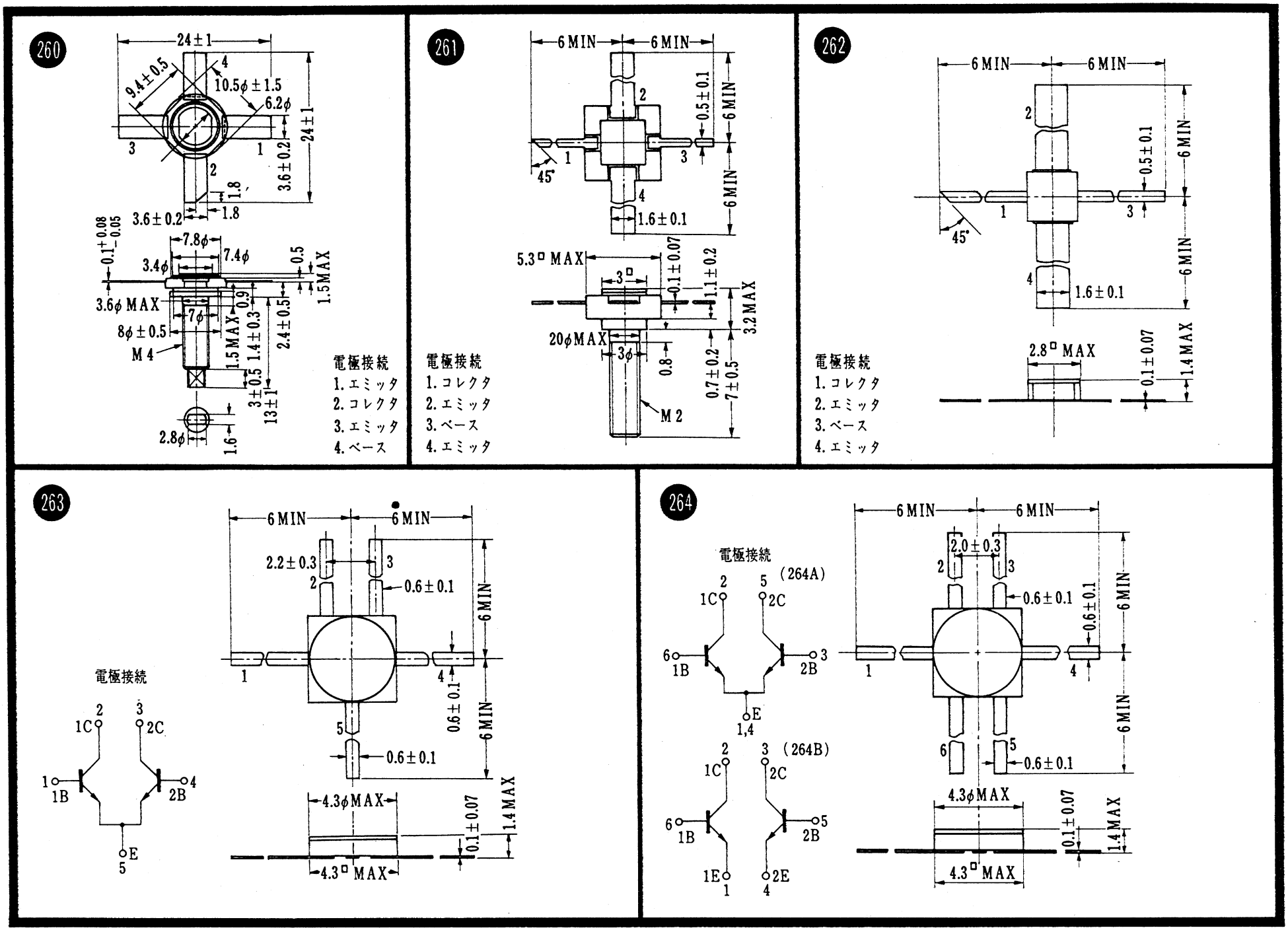
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

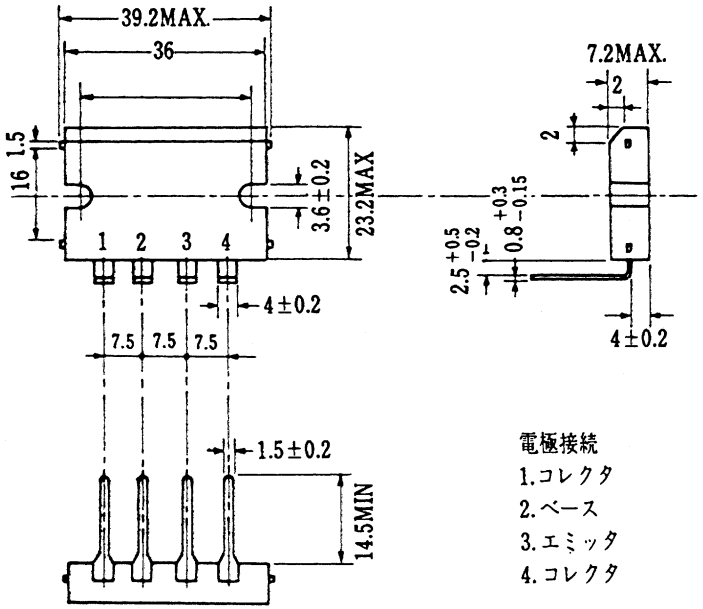
〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

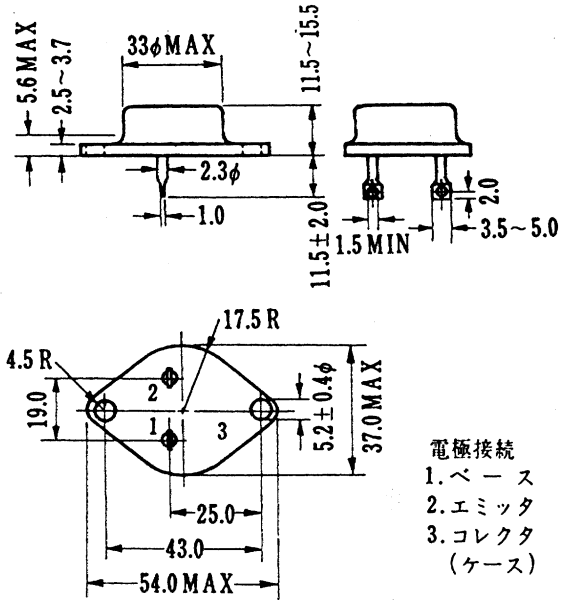
〈寸法図単位：mm〉

265



電極接続
1.コレクタ
2.ベース
3.エミッタ
4.コレクタ

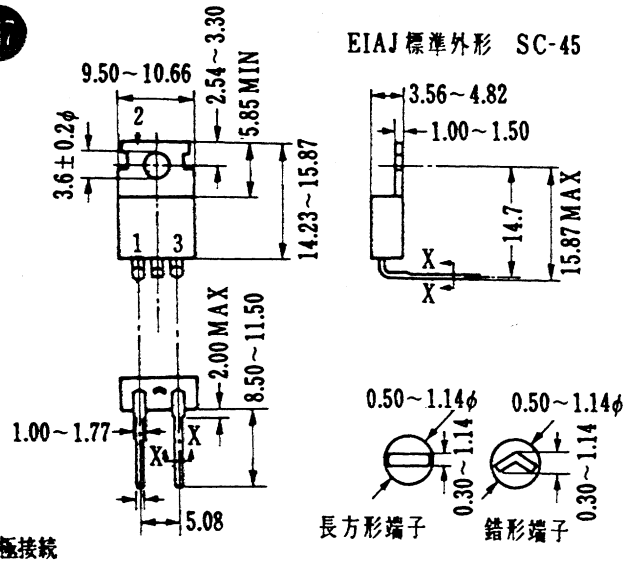
266



電極接続
1.ベース
2.エミッタ
3.コレクタ
(ケース)

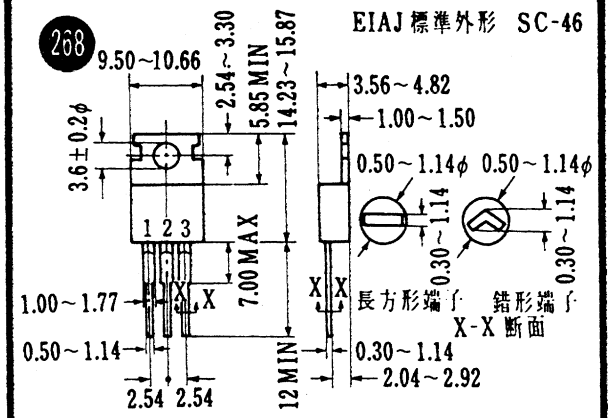
EIAJ標準外形
TC-19
TB-30

267



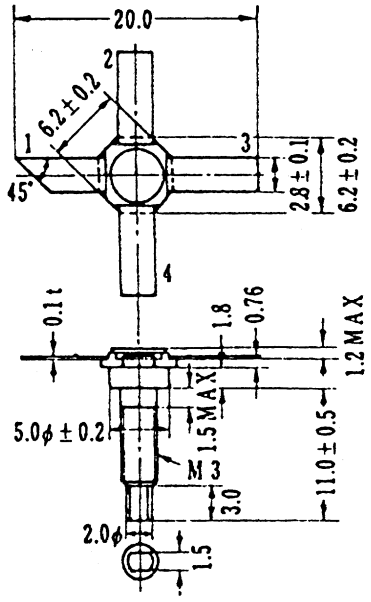
電極接続
1.ベース
2.コレクタ
3.エミッタ

268



外形番号	電極接続 1	2	3
268	ベース	コレクタ(フランジ)	エミッタ
268A	コレクタ(フランジ)	エミッタ	ベース
268B	ベース	エミッタ(フランジ)	コレクタ
268C	コレクタ	エミッタ(フランジ)	ベース
268D	コレクタ	ベース(フランジ)	エミッタ

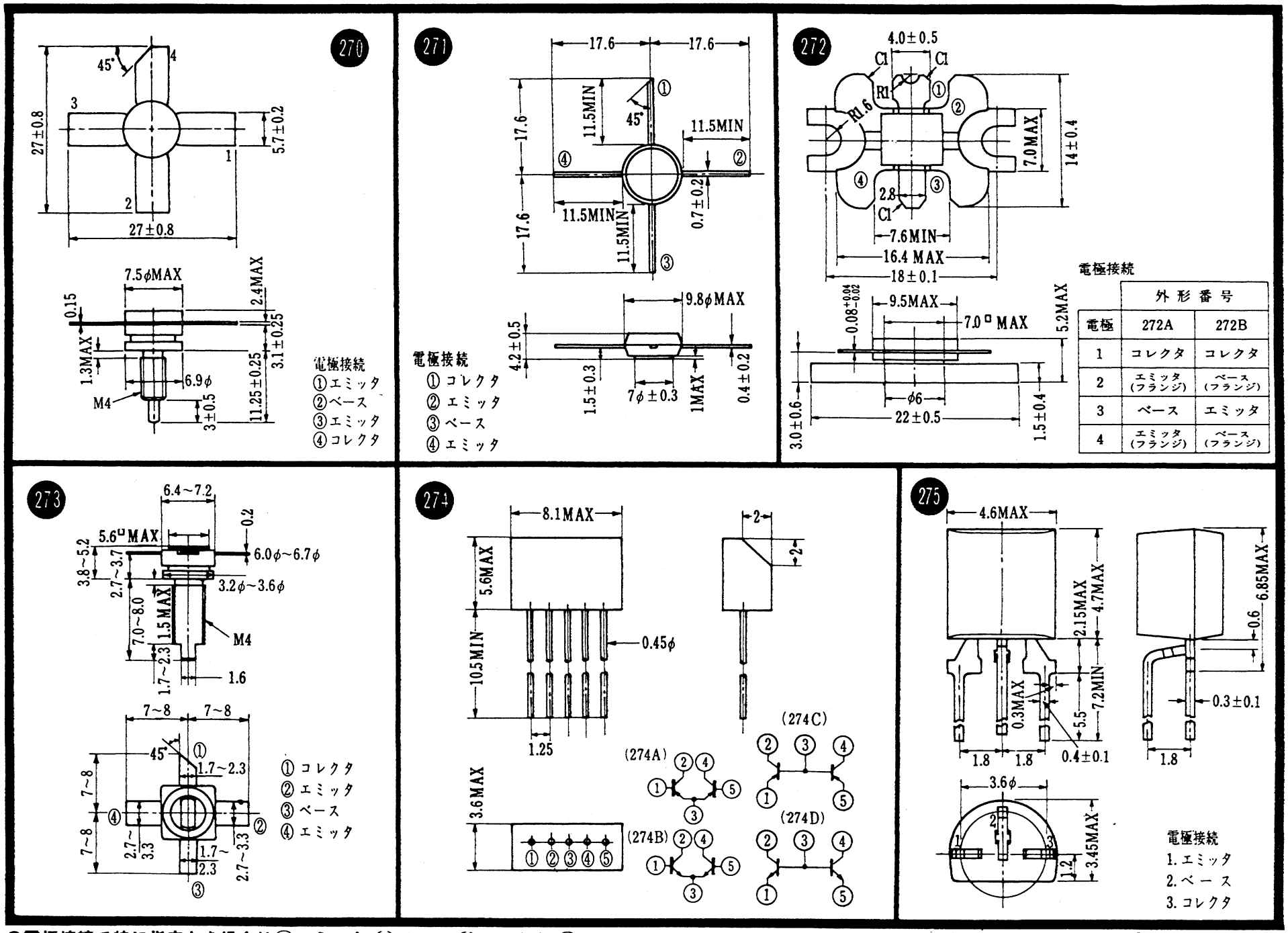
269



電極接続
1.コレクタ
2.エミッタ
3.ベース
4.エミッタ

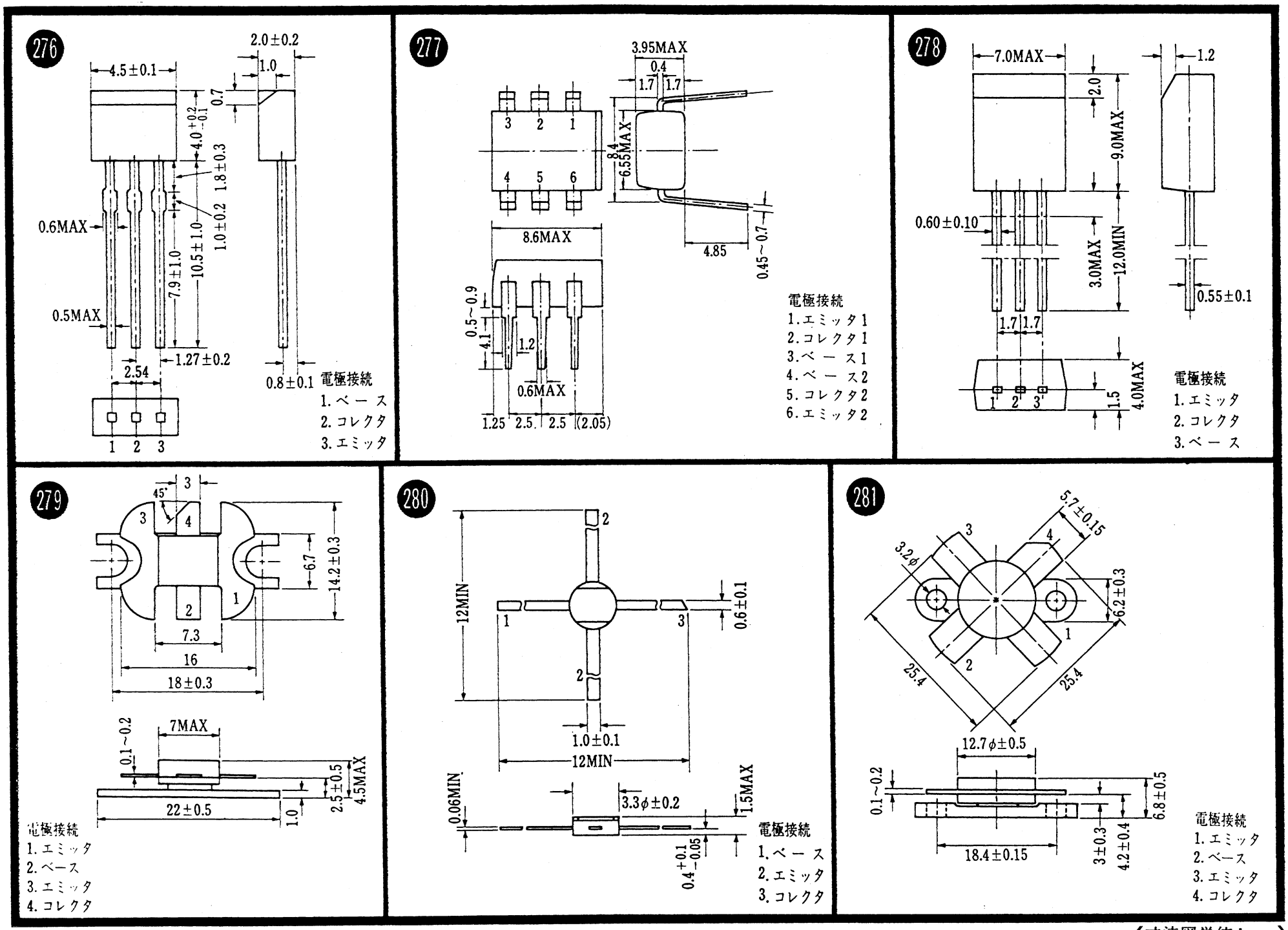
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



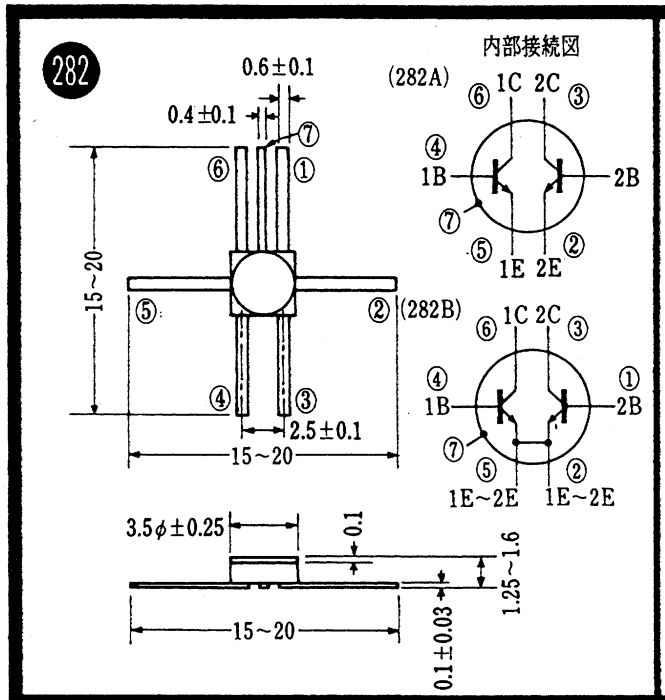
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

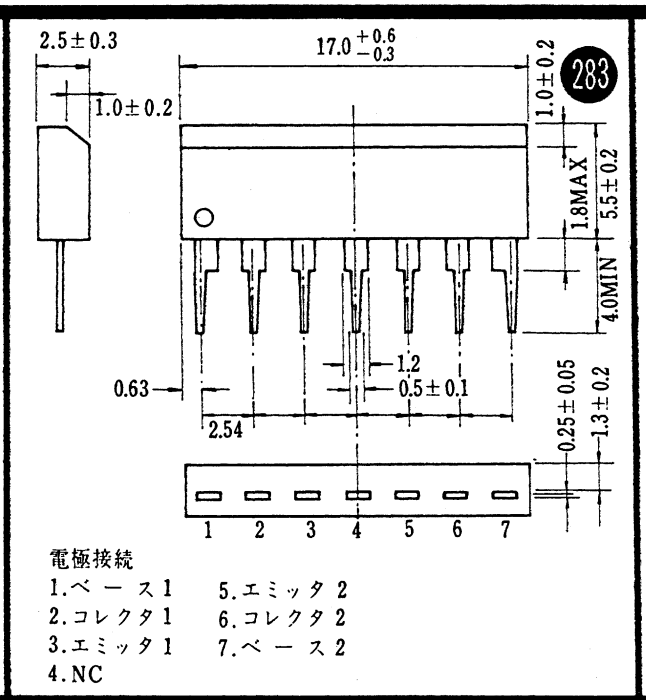
〈寸法図単位：mm〉

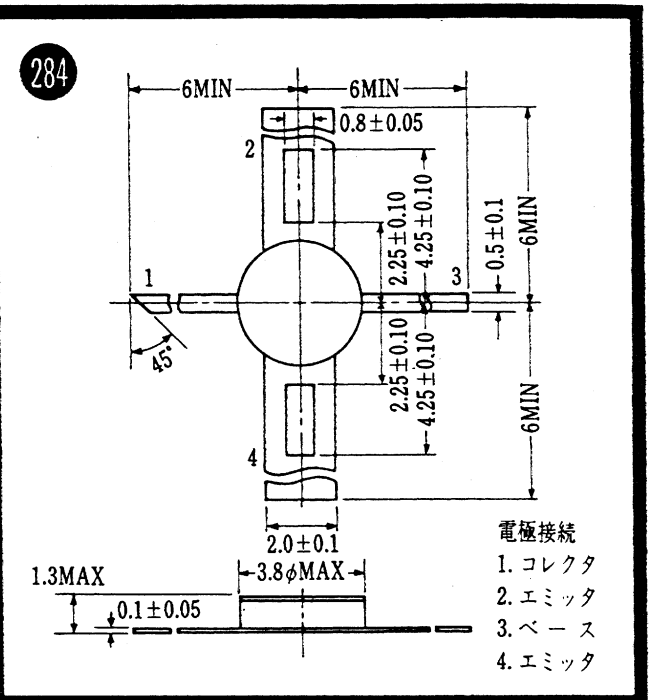


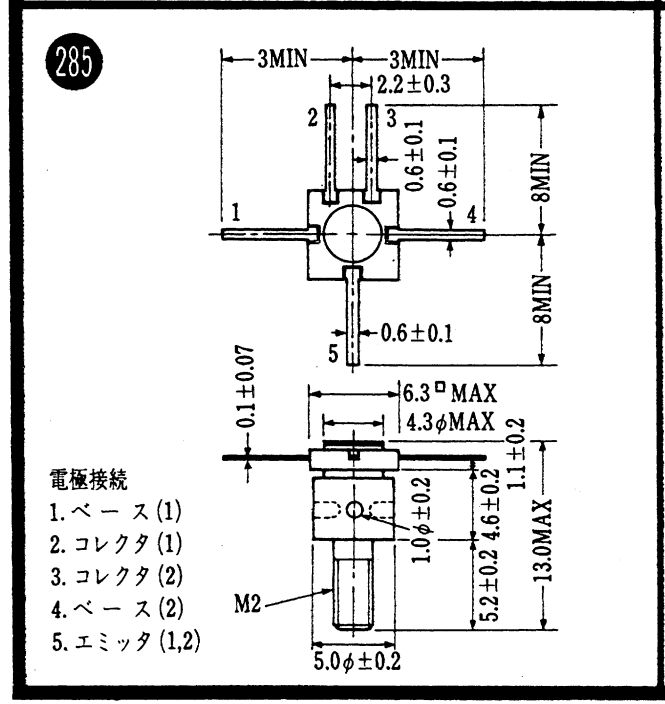
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

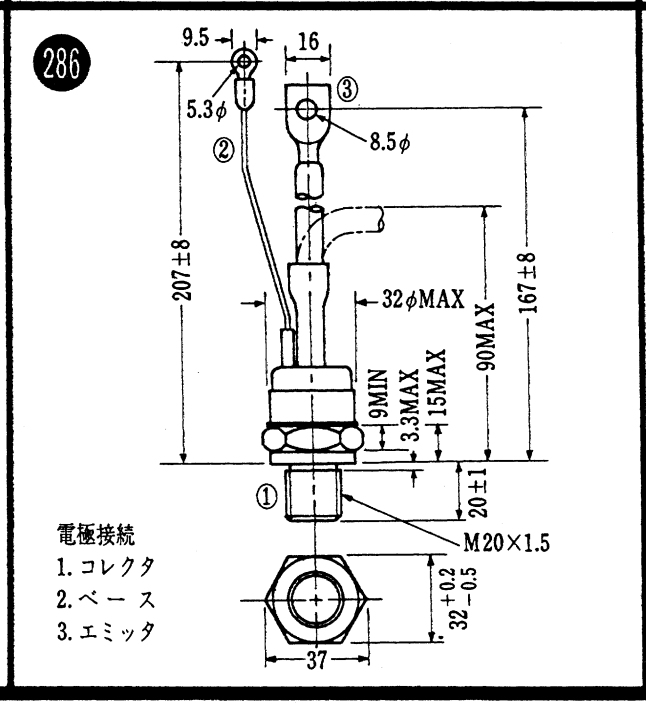
〈寸法図単位：mm〉

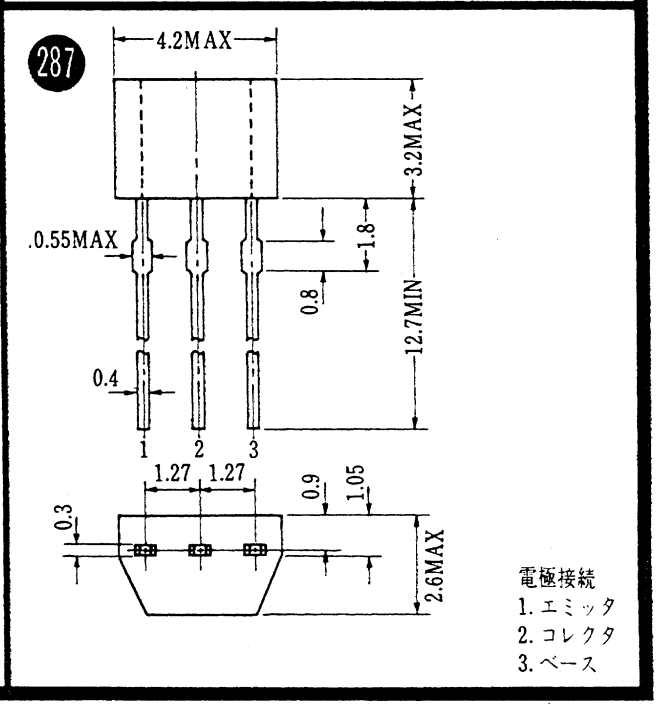






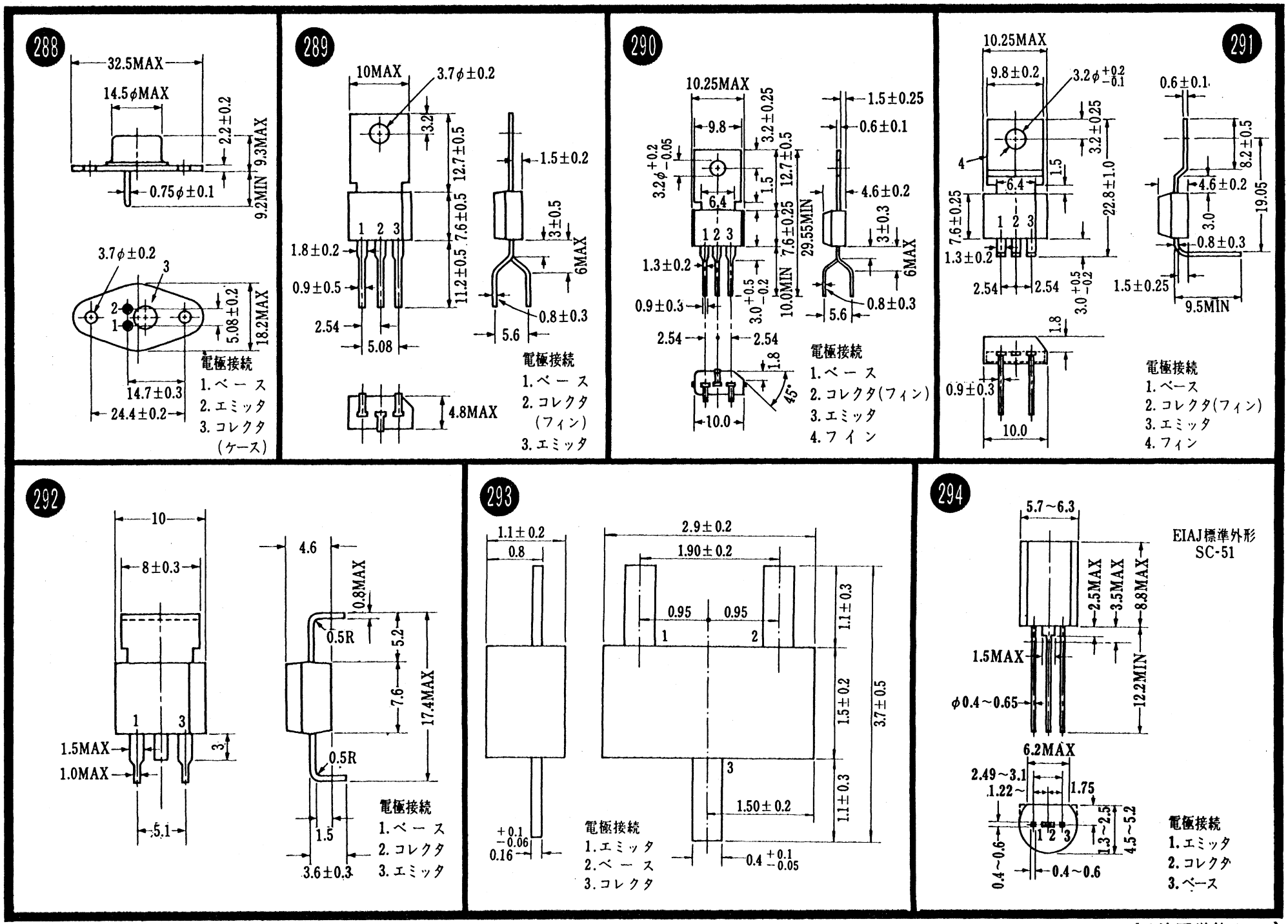






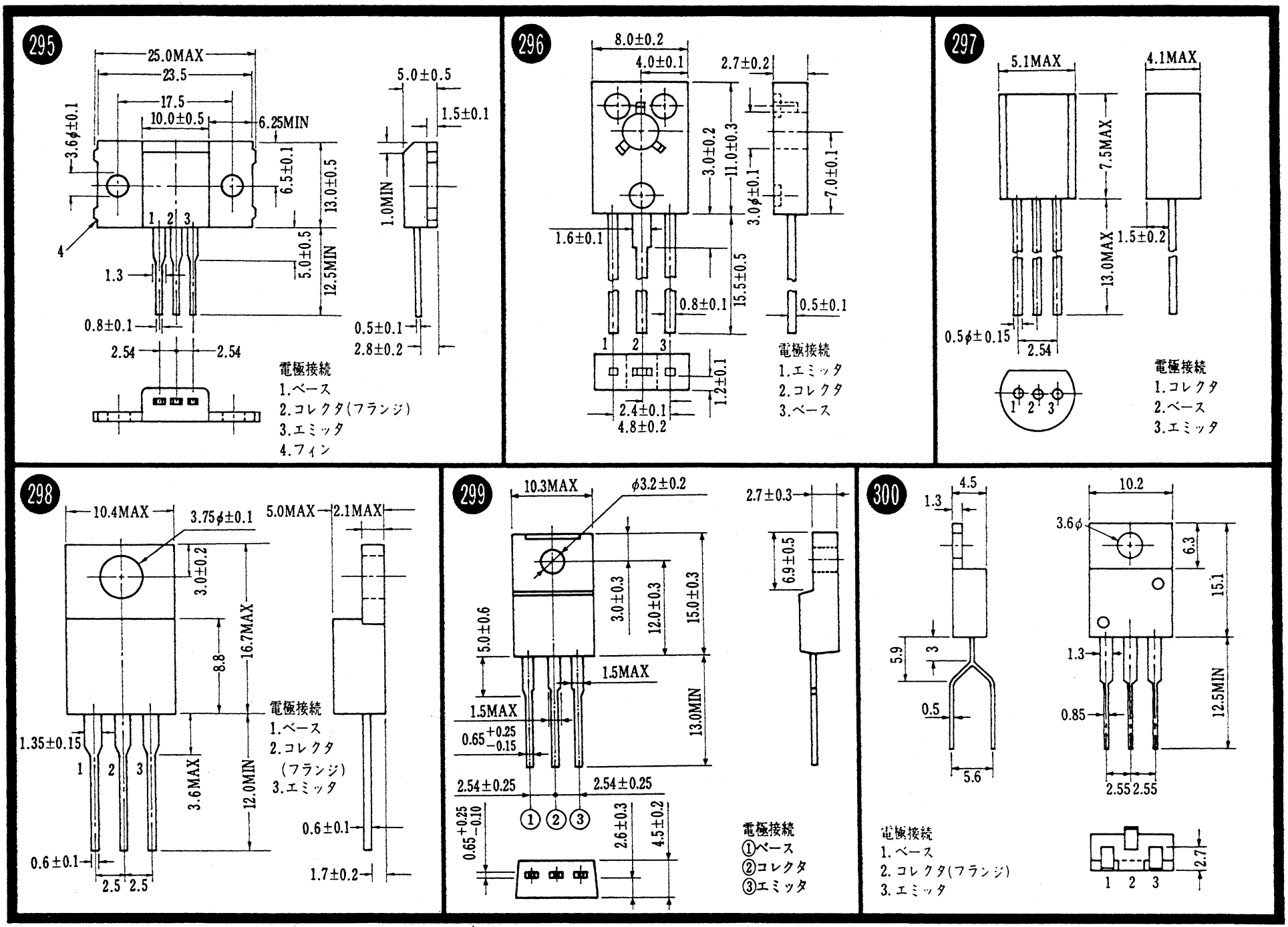
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

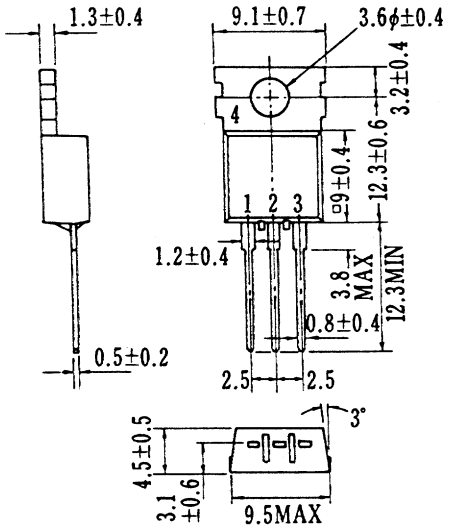
《寸法図単位：mm》



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

《寸法図単位：mm》

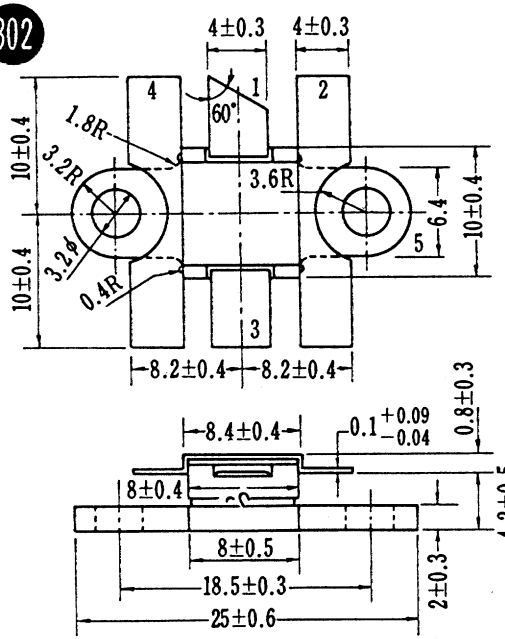
301



電極接続

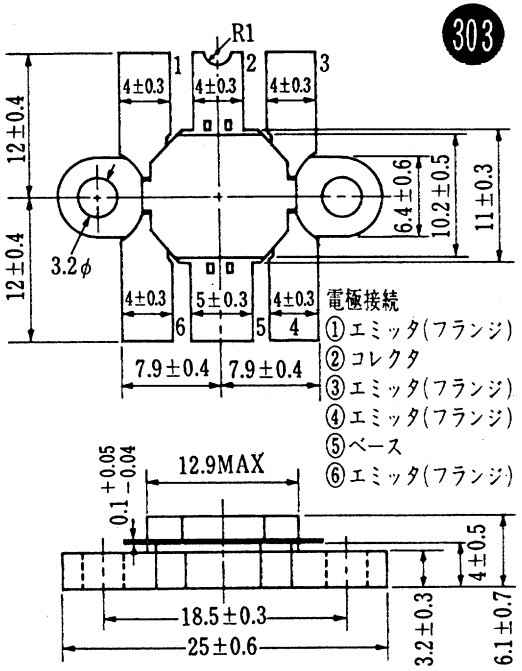
外形番号	電極接続			
	1	2	3	4
301A	ベース	エミッタ	コレクタ	エミッタ(フランジ)
301B	ベース	コレクタ	エミッタ	コレクタ(フランジ)

302



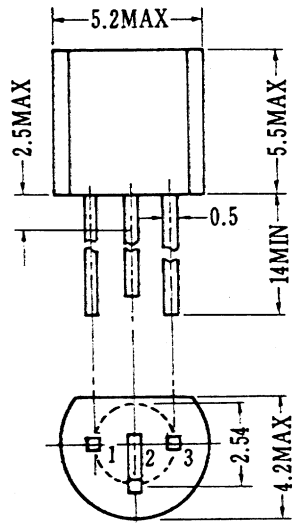
電極接続
1.コレクタ
2.エミッタ
3.ベース
4.エミッタ
5.エミッタ(フランジ)

303



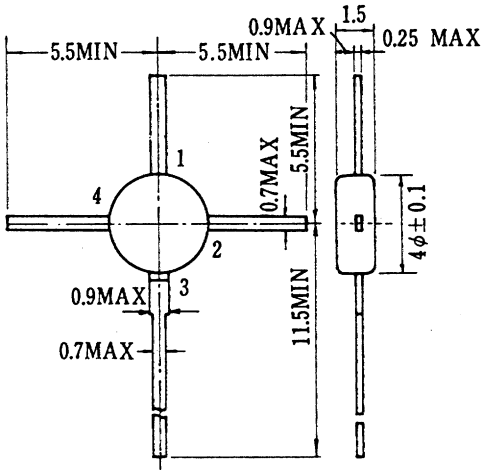
電極接続
①エミッタ(フランジ)
②コレクタ
③エミッタ(フランジ)
④エミッタ(フランジ)
⑤ベース
⑥エミッタ(フランジ)

304



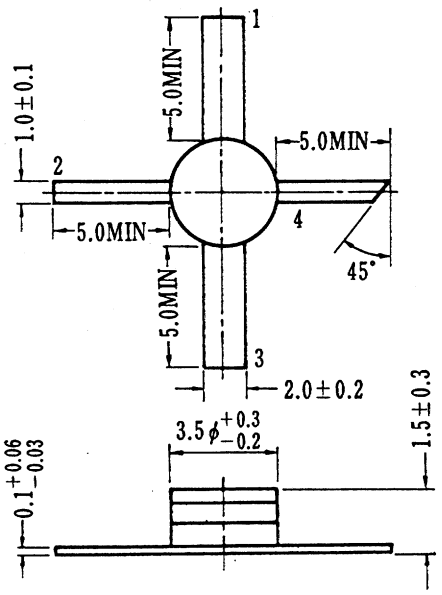
電極接続
1.コレクタ
2.ベース
3.エミッタ

305



外形番号	電極接続			
	1	2	3	4
305A	エミッタ	ベース	コレクタ	ベース
305B	ベース	エミッタ	コレクタ	エミッタ

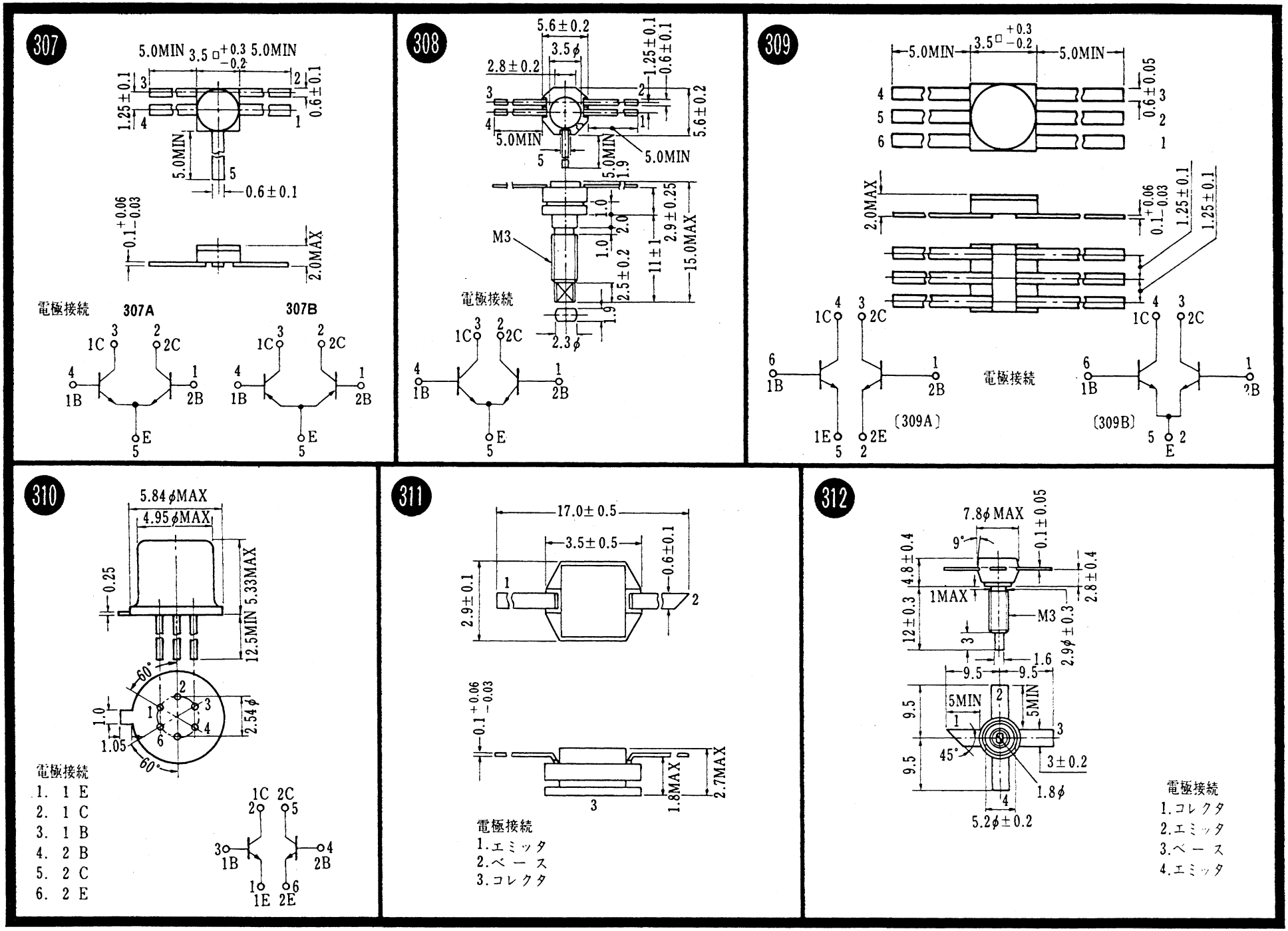
306



電極接続
1.エミッタ
2.コレクタ
3.エミッタ
4.ベース

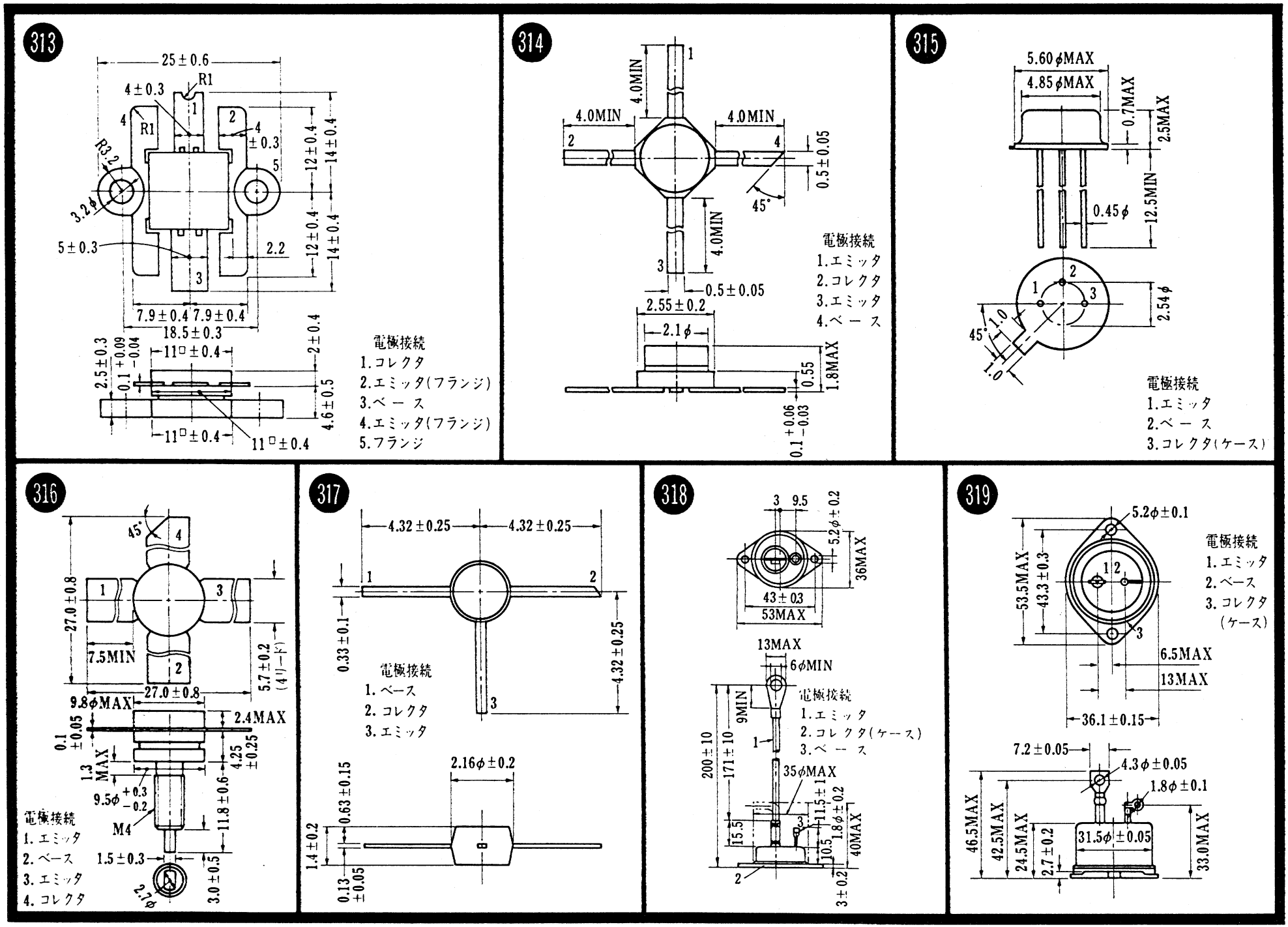
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ，②ベース，③コレクタ，④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



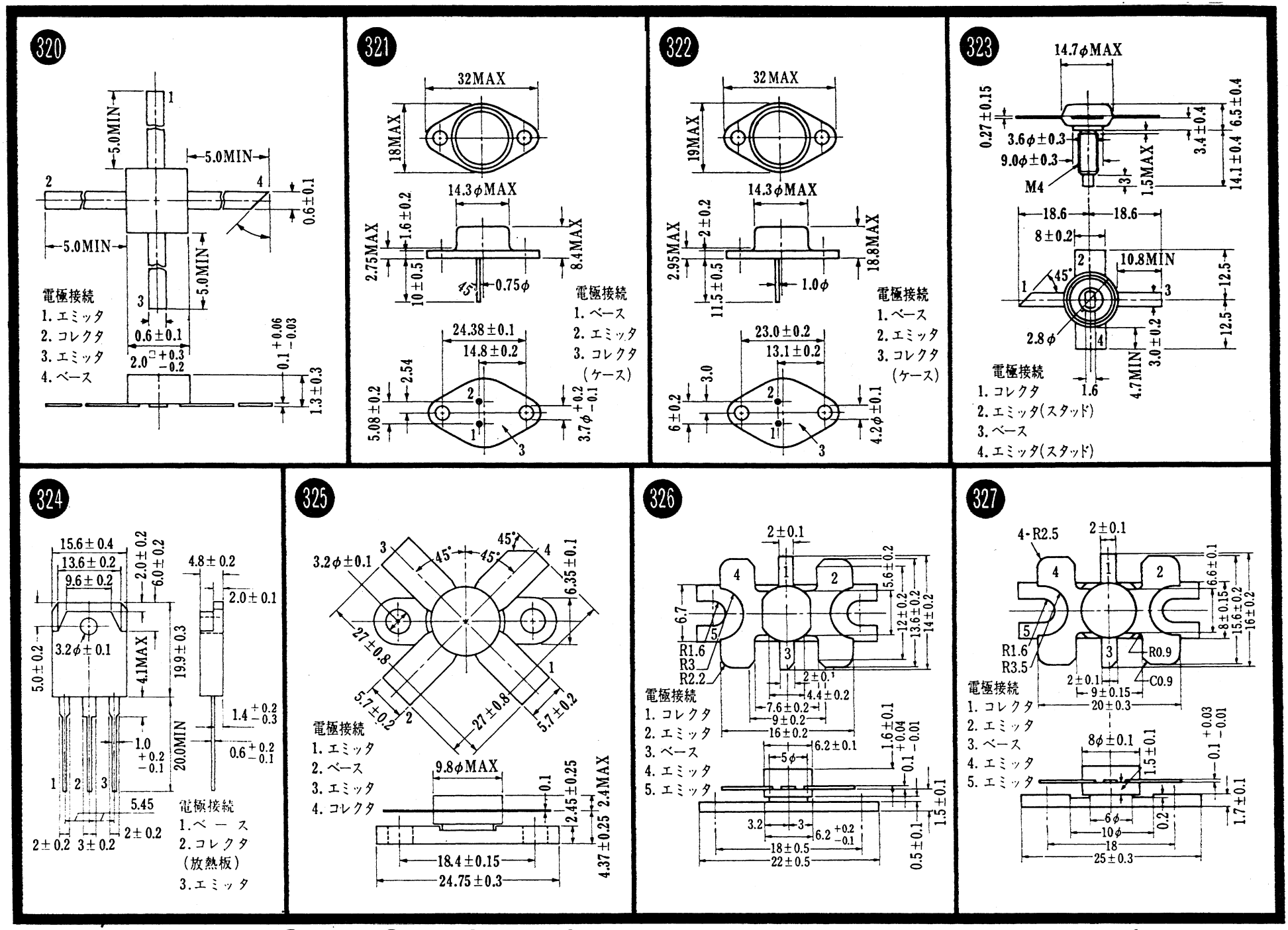
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ，②ベース，③コレクタ，④シールドです

《寸法図単位：mm》



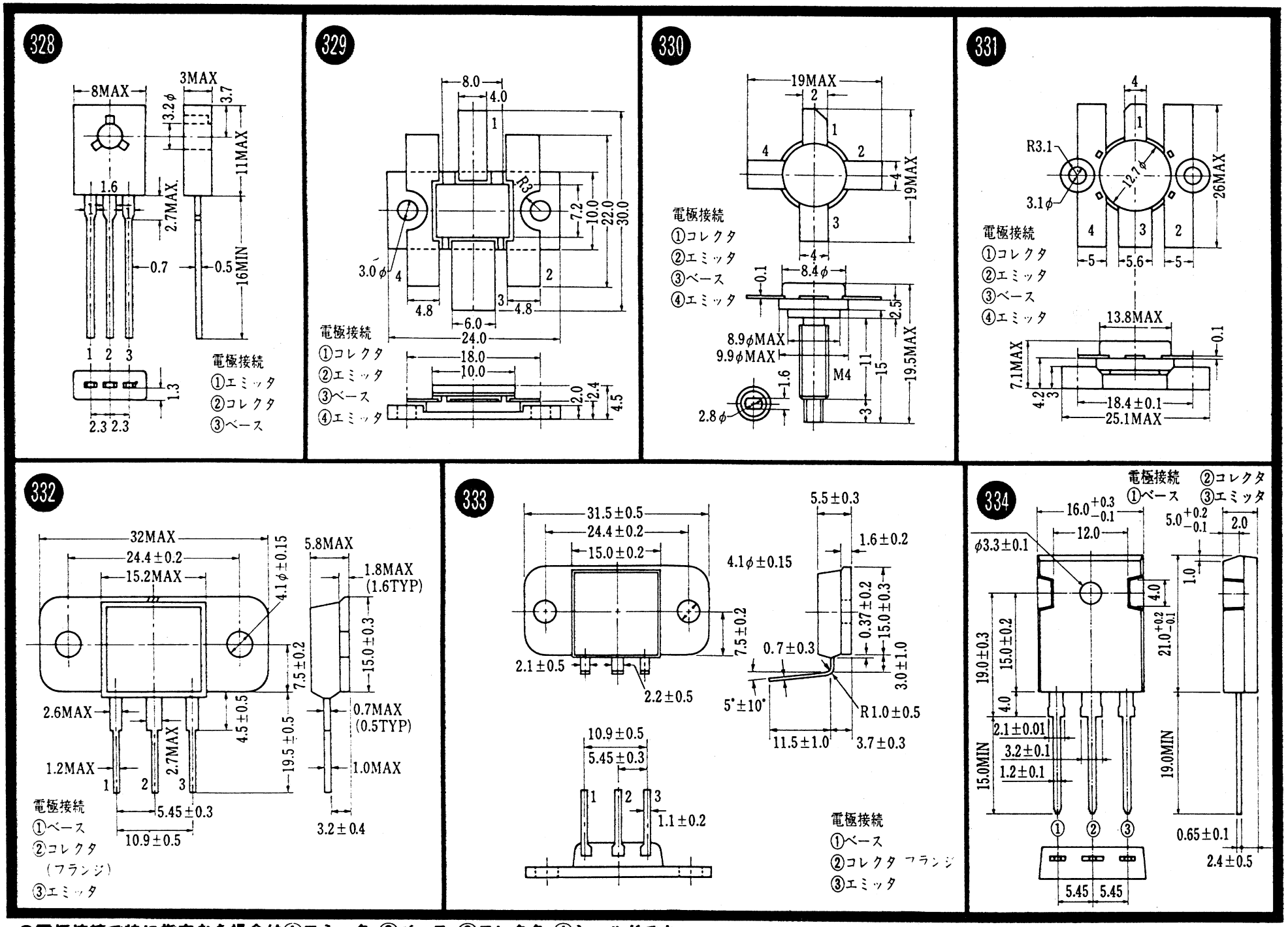
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

《寸法図単位：mm》



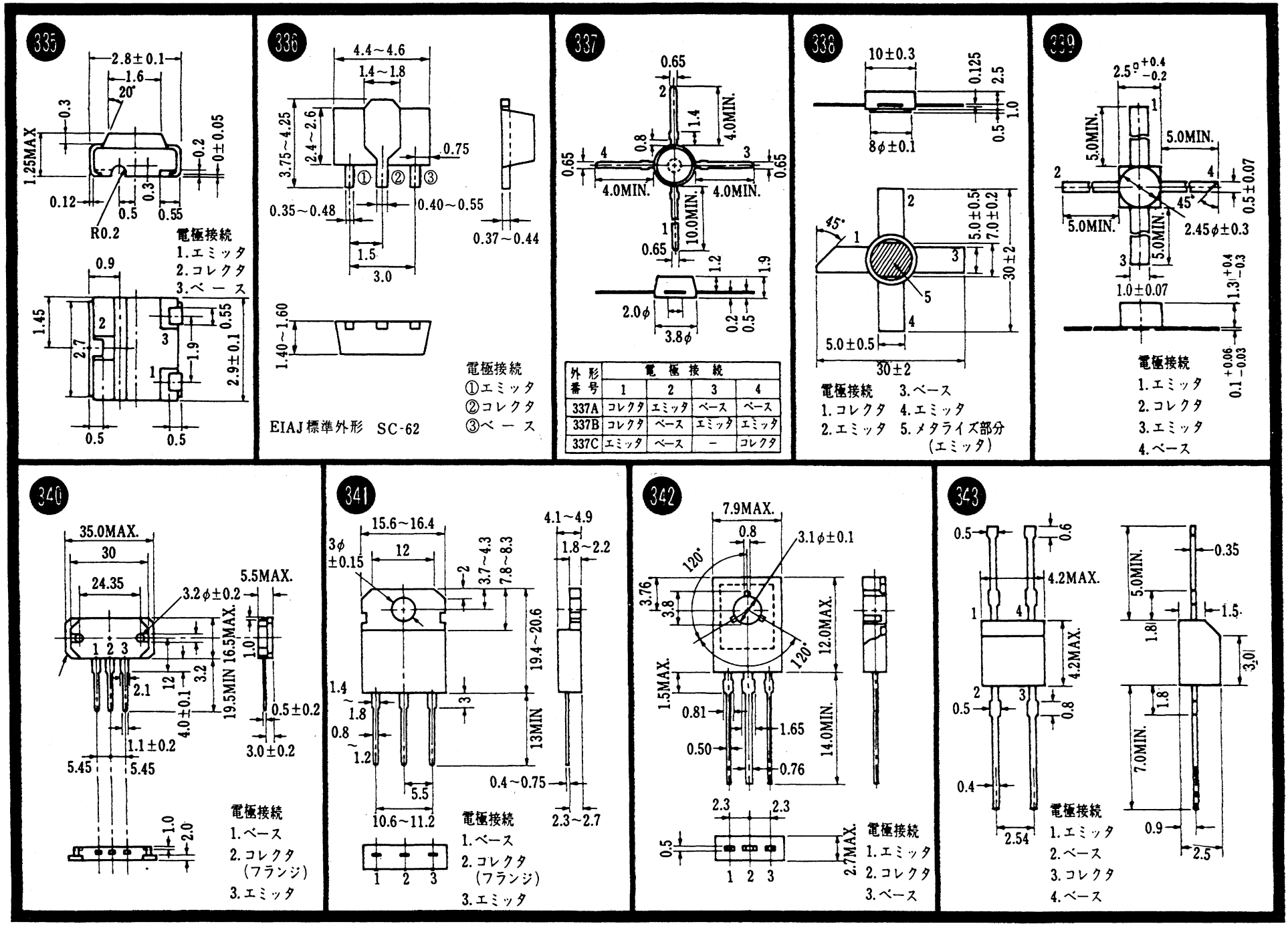
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉

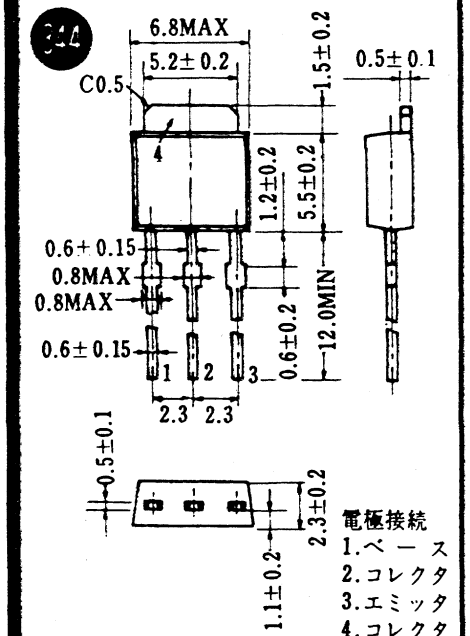


外形番号	電極接続 1	2	3	4
337A	コレクタ	エミッタ	ベース	ベース
337B	コレクタ	ベース	エミッタ	エミッタ
337C	エミッタ	ベース	−	コレクタ

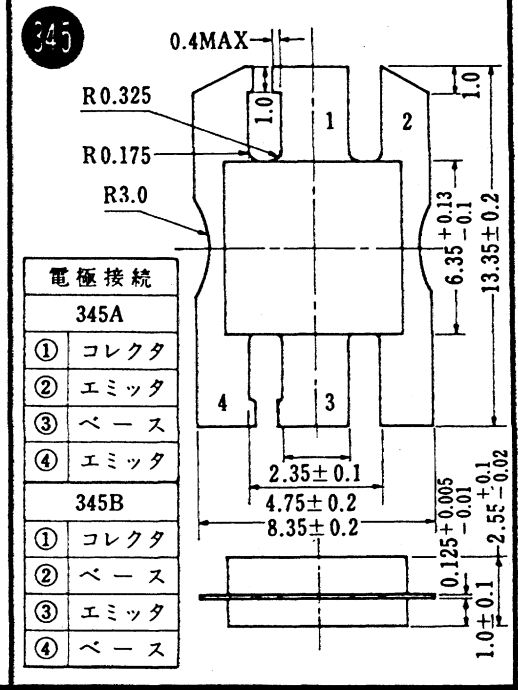
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉

344

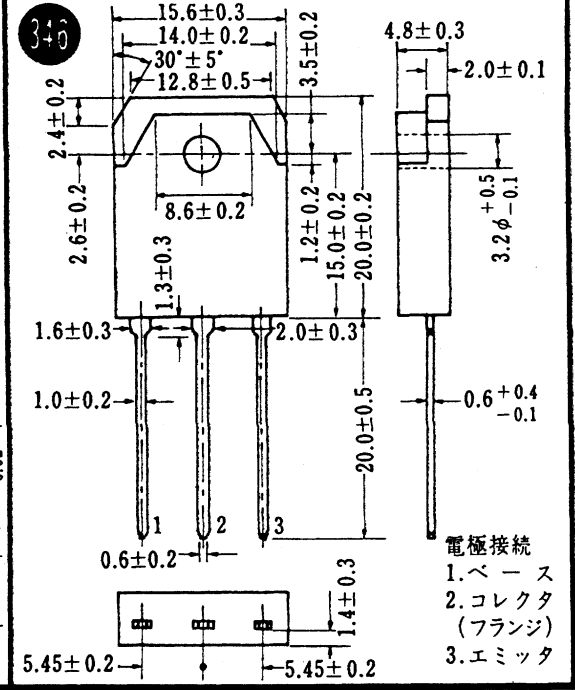


345

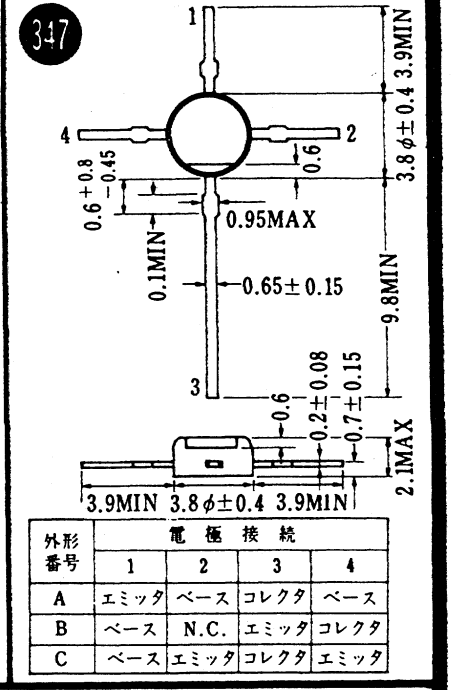


電極接続	
345A	
①	コレクタ
②	エミッタ
③	ベース
④	エミッタ
345B	
①	コレクタ
②	ベース
③	エミッタ
④	ベース

346

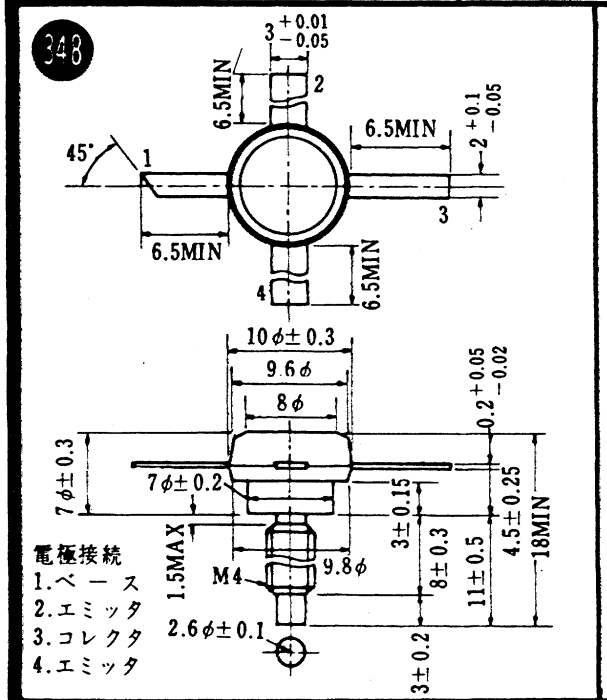


347

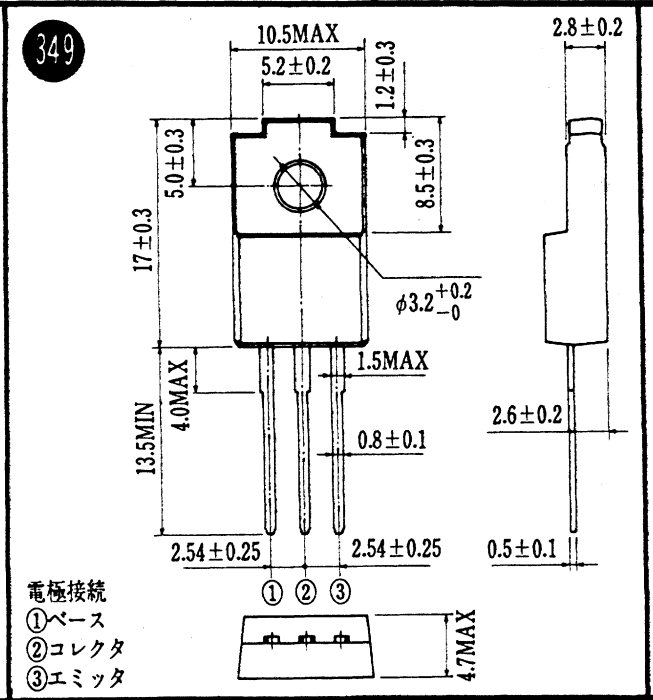


外形番号	電極接続 1	2	3	4
A	エミッタ	ベース	コレクタ	ベース
B	ベース	N.C.	エミッタ	コレクタ
C	ベース	エミッタ	コレクタ	エミッタ

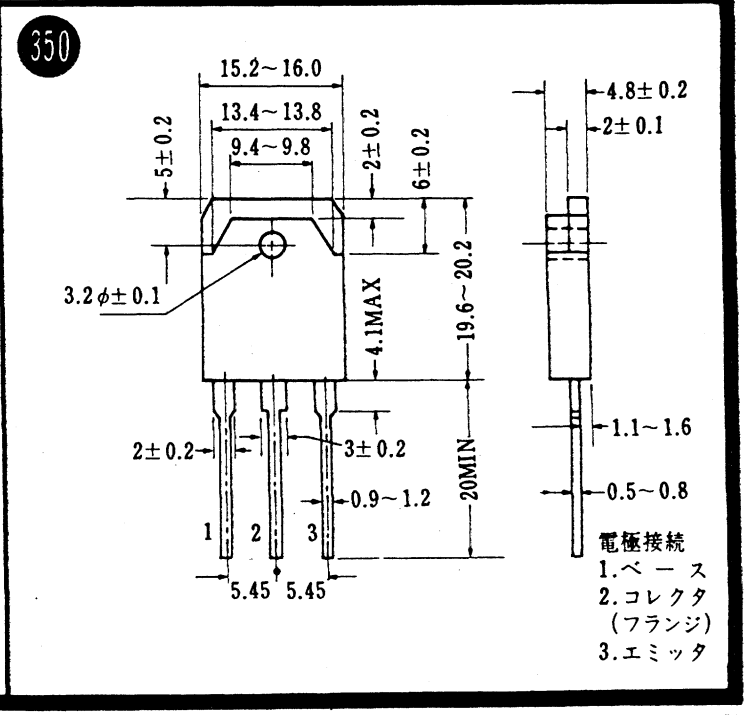
348



349

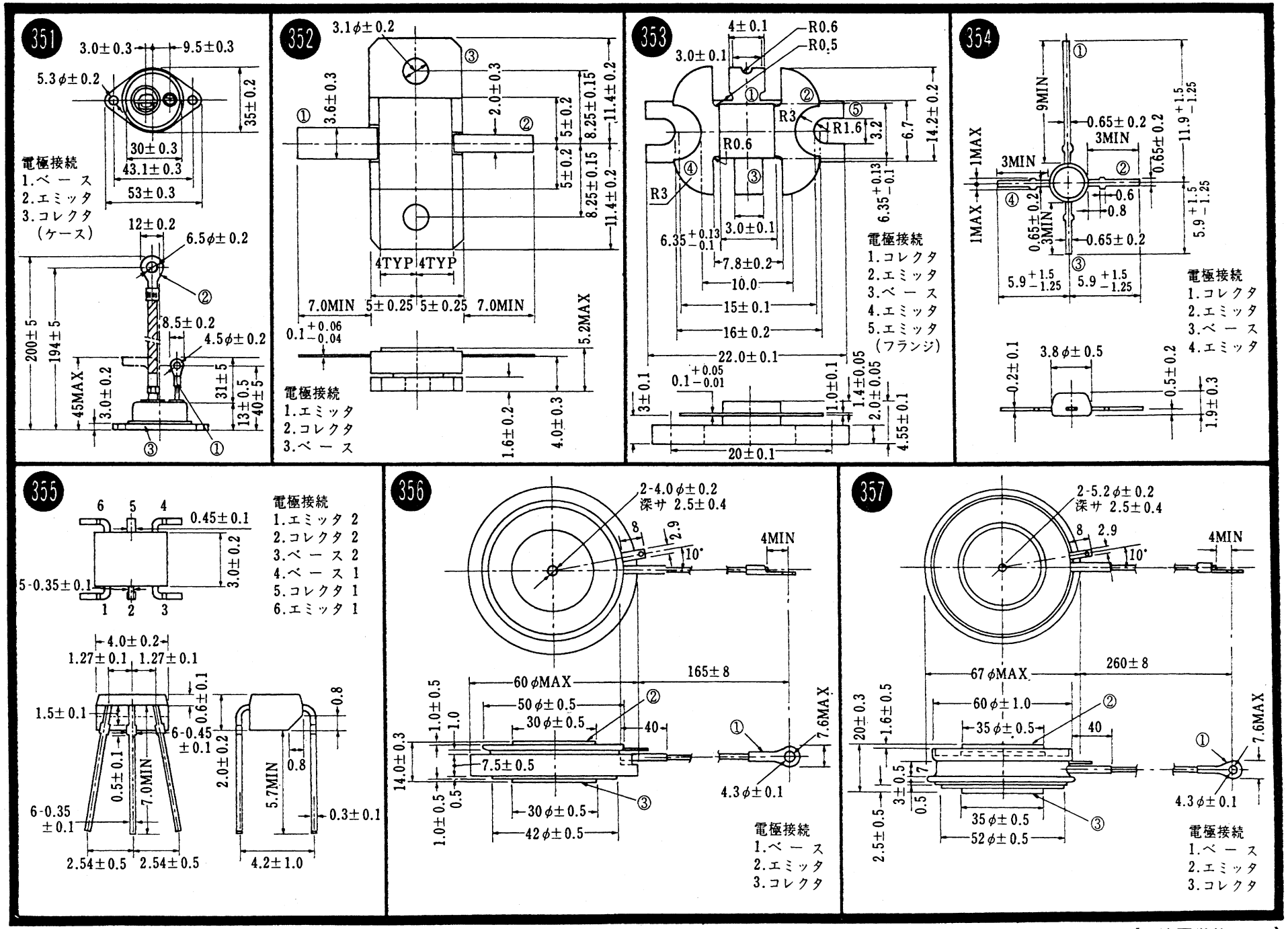


350



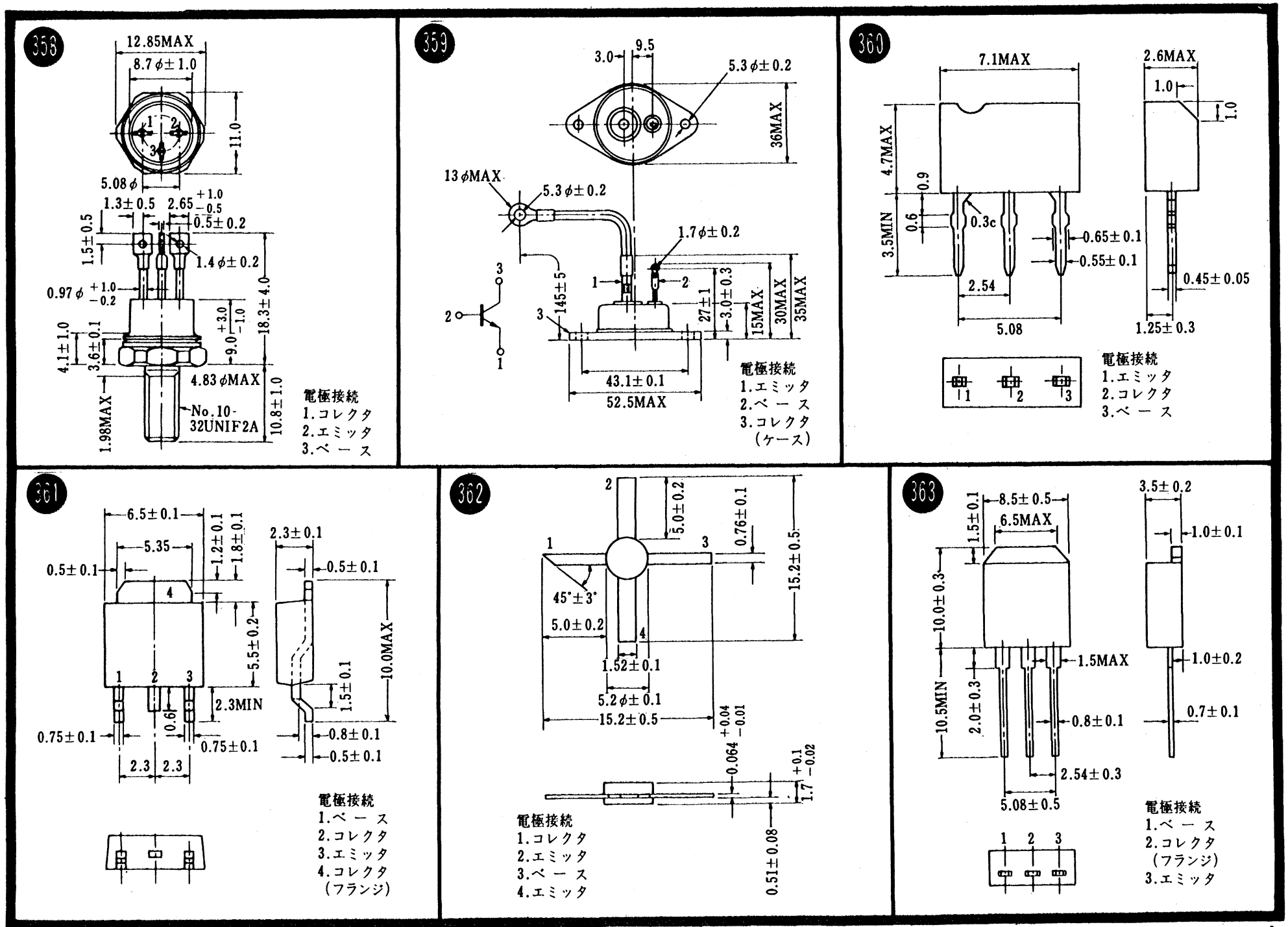
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ，②ベース，③コレクタ，④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



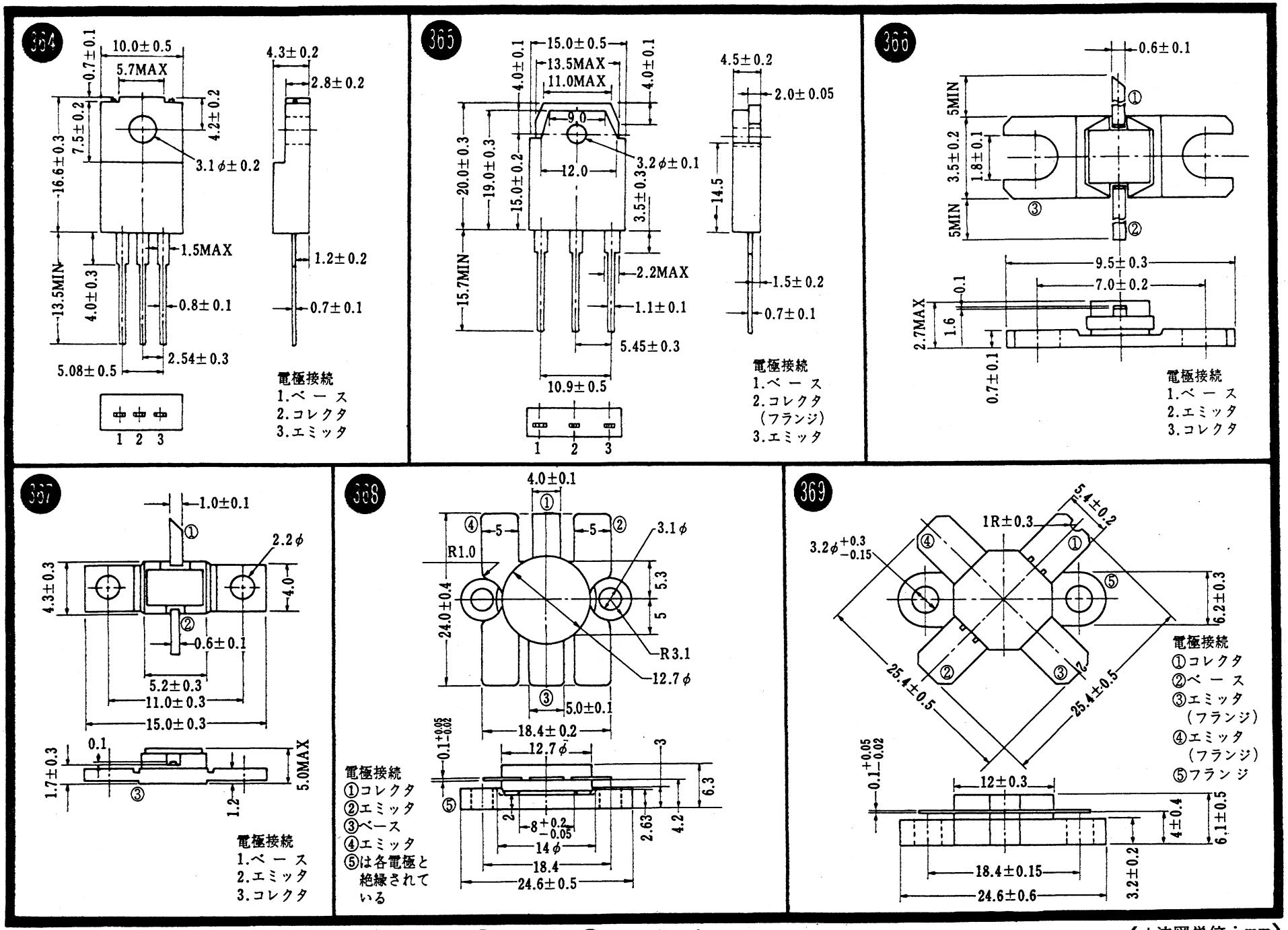
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ，②ベース，③コレクタ，④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



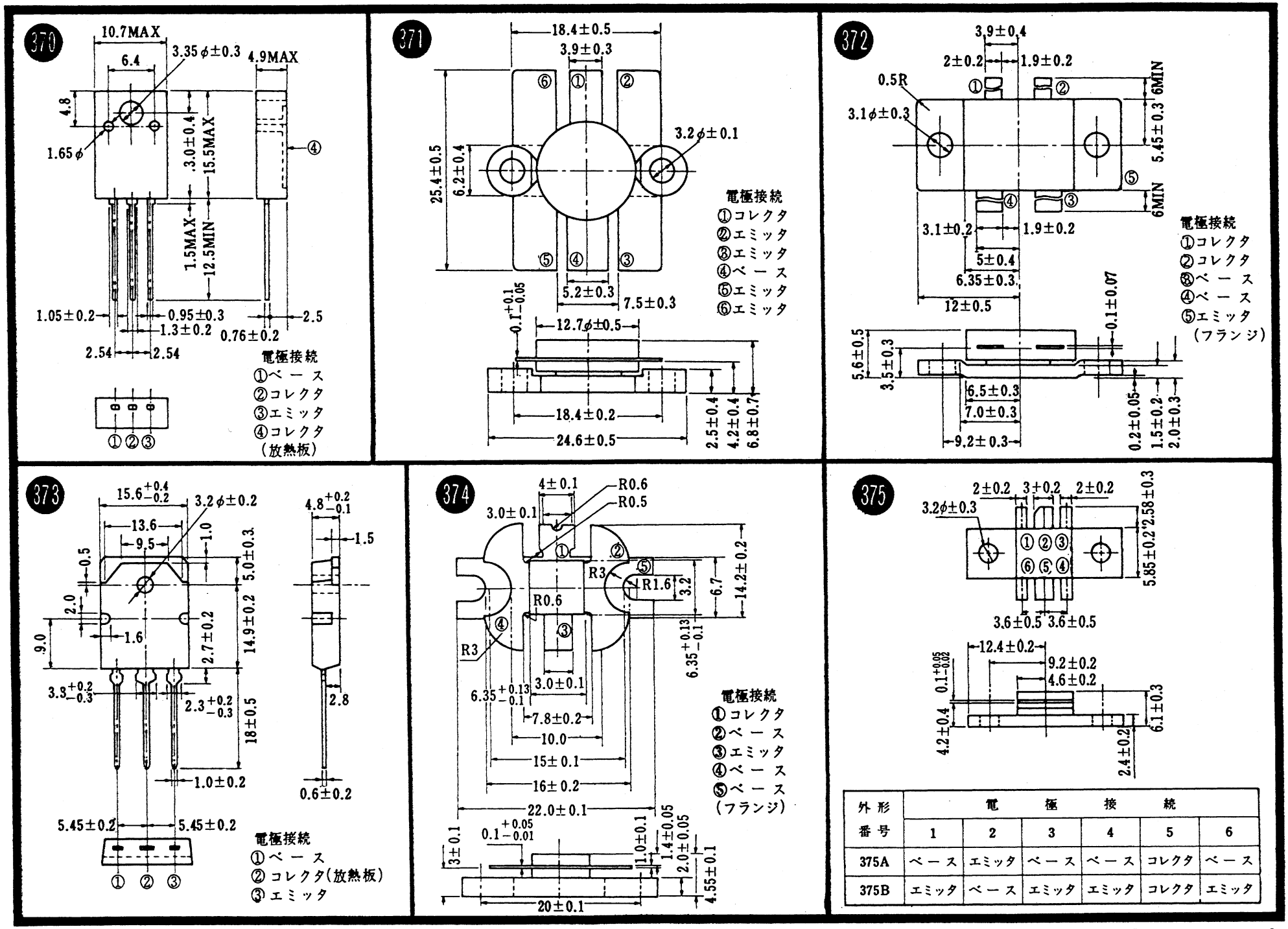
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ，②ベース，③コレクタ，④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ，②ベース，③コレクタ，④シールドです

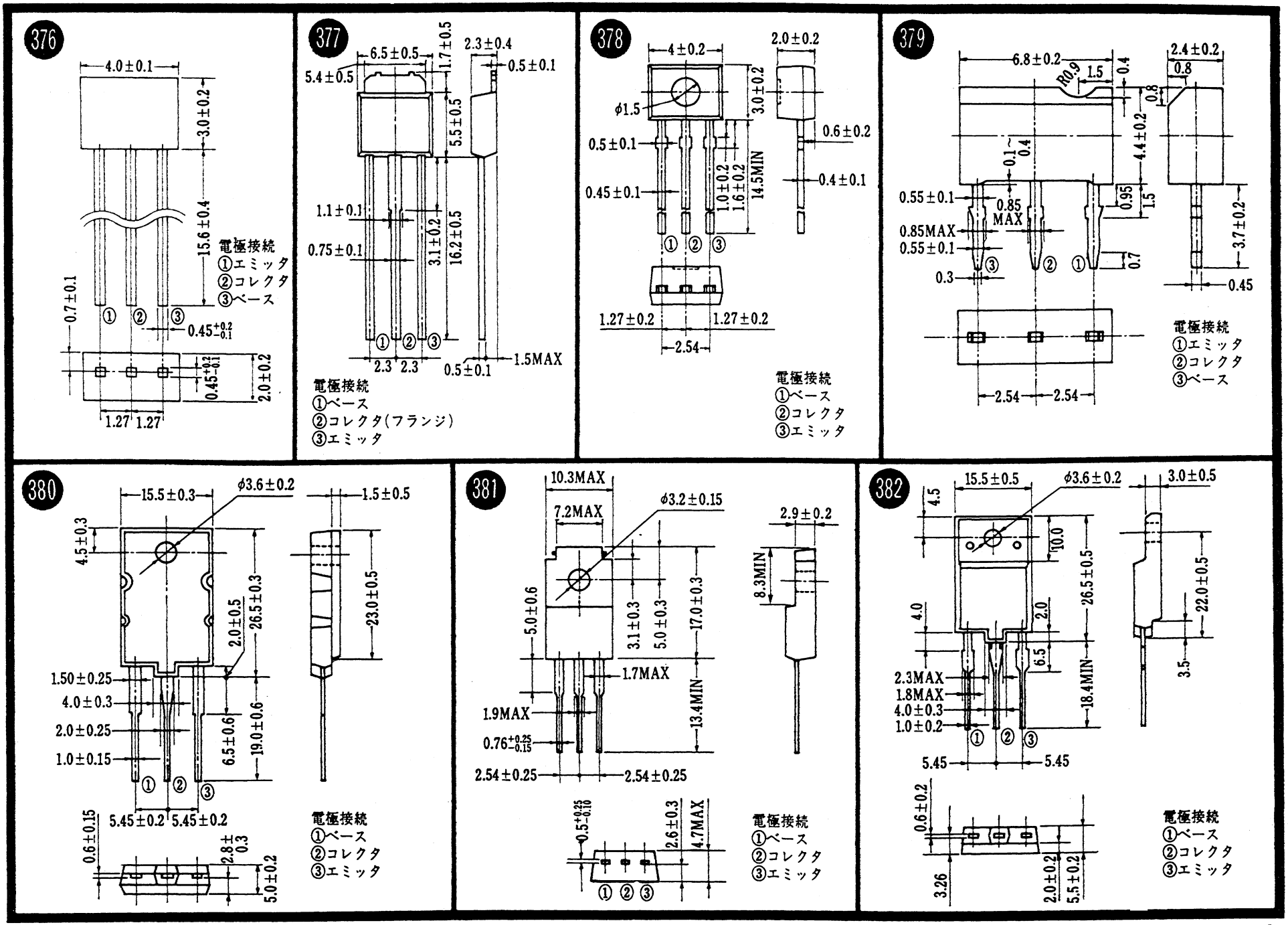
〈寸法図単位：mm〉



外形番号	電極接続					
	1	2	3	4	5	6
375A	ベース	エミッタ	ベース	ベース	コレクタ	ベース
375B	エミッタ	ベース	エミッタ	エミッタ	コレクタ	エミッタ

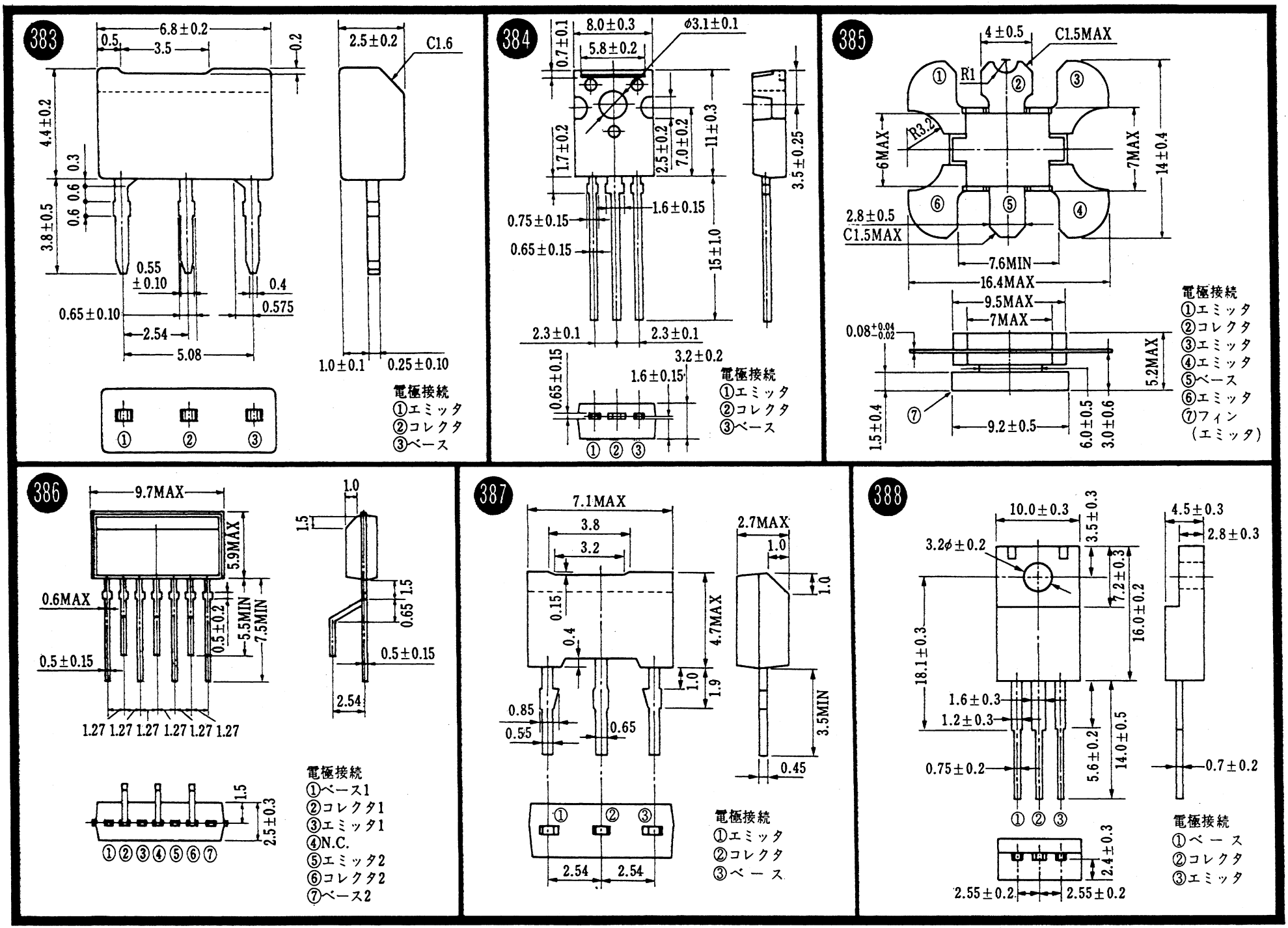
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ，②ベース，③コレクタ，④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



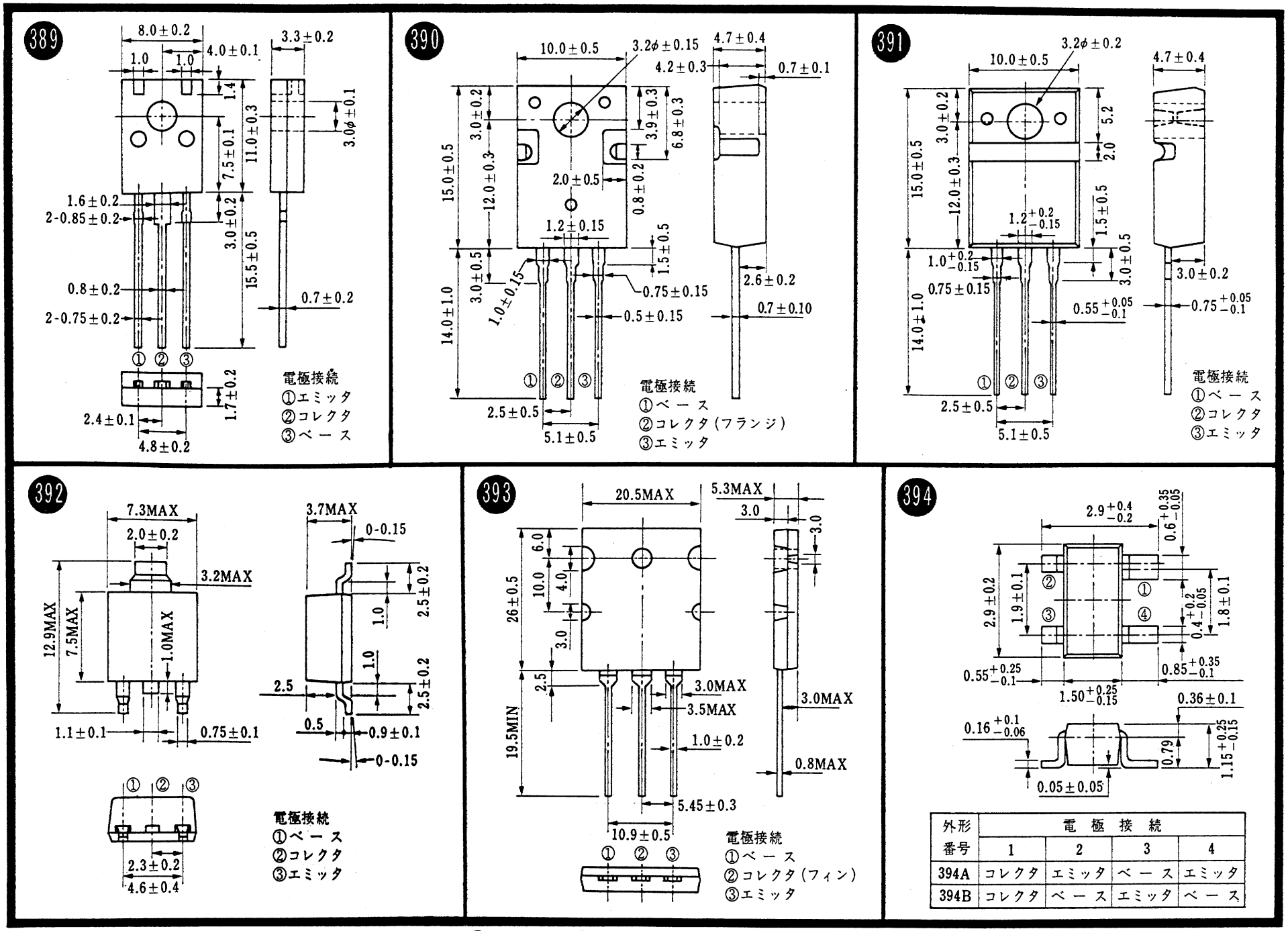
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

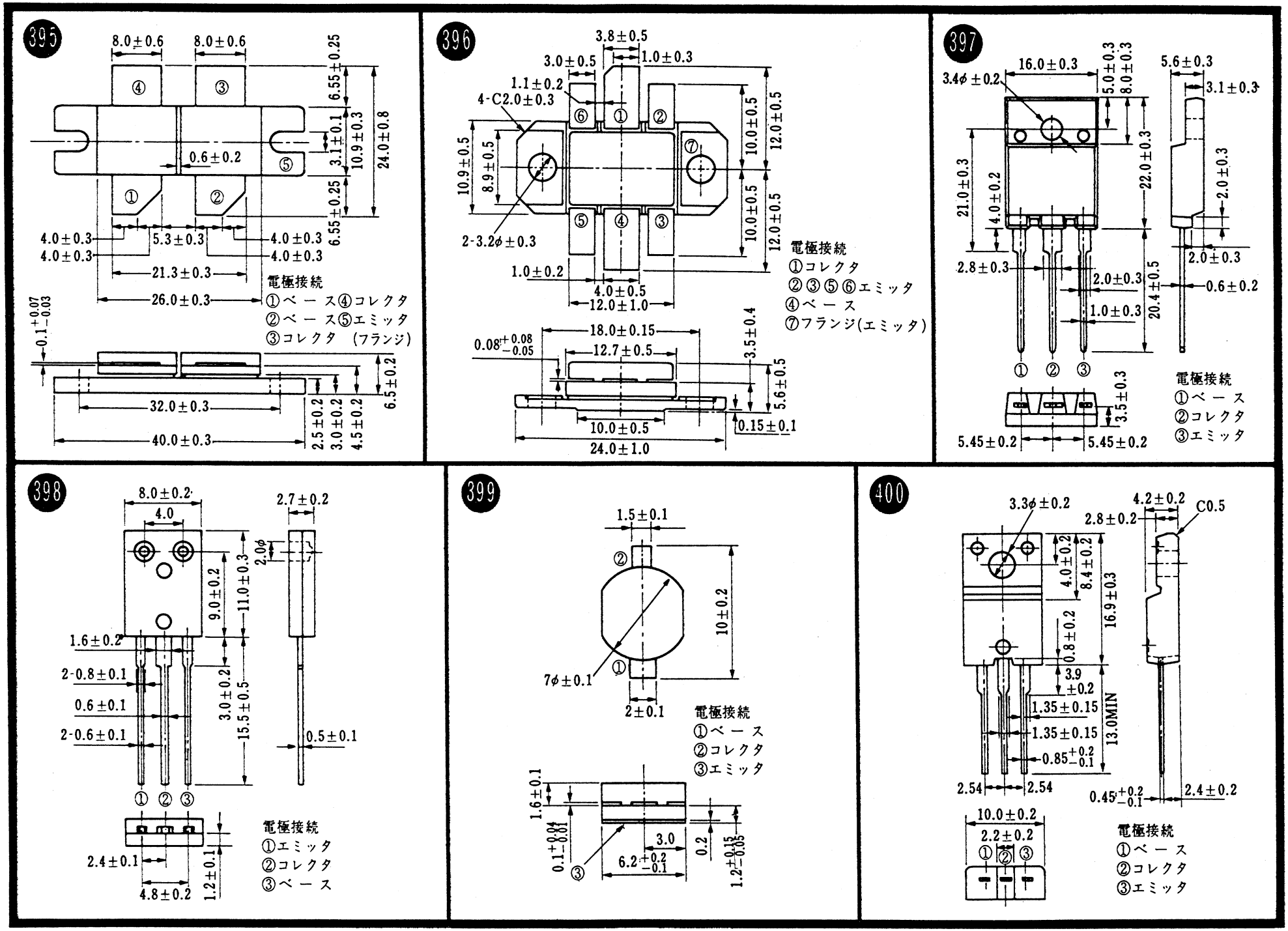
《寸法図単位：mm》



外形番号	電極接続 1	2	3	4
394A	コレクタ	エミッタ	ベース	エミッタ
394B	コレクタ	ベース	エミッタ	ベース

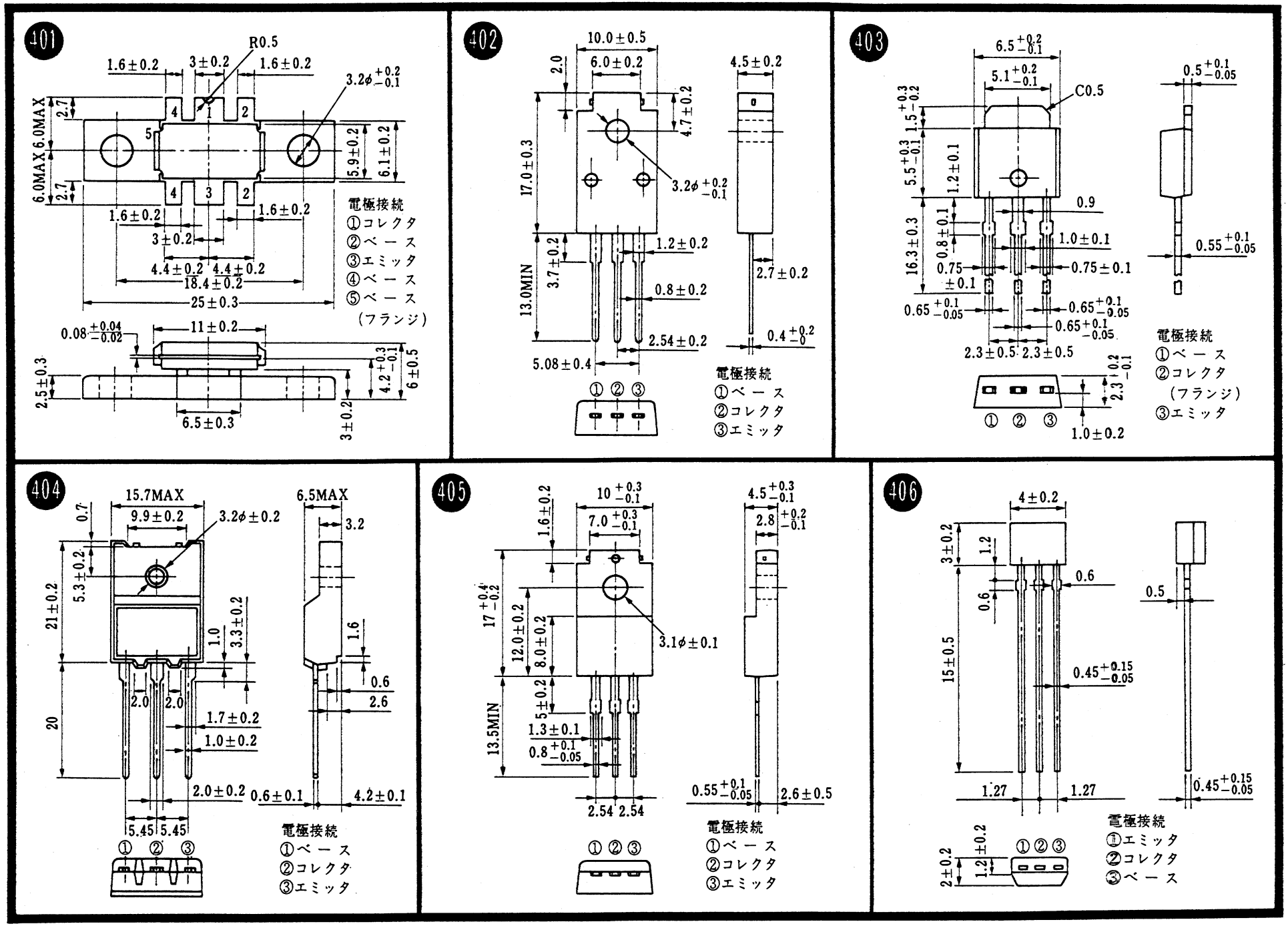
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

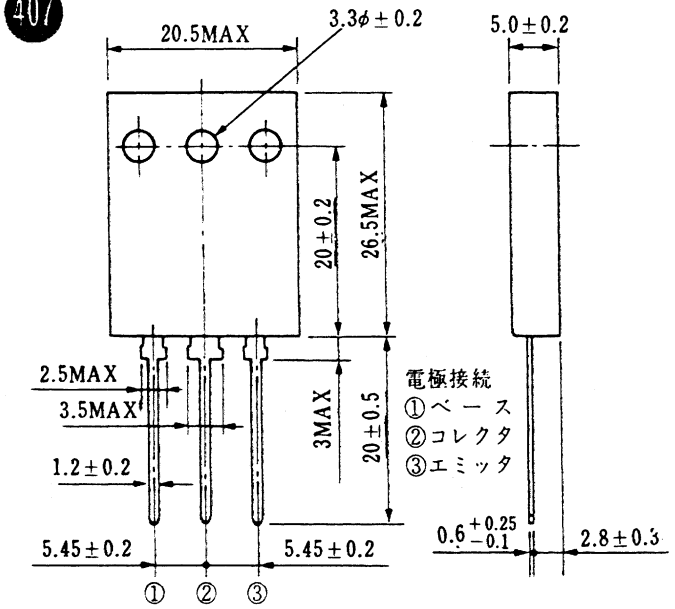
〈寸法図単位：mm〉



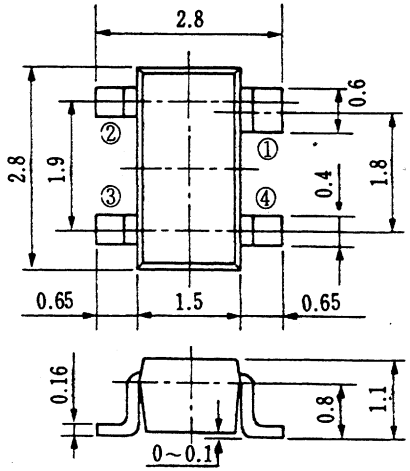
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉

407

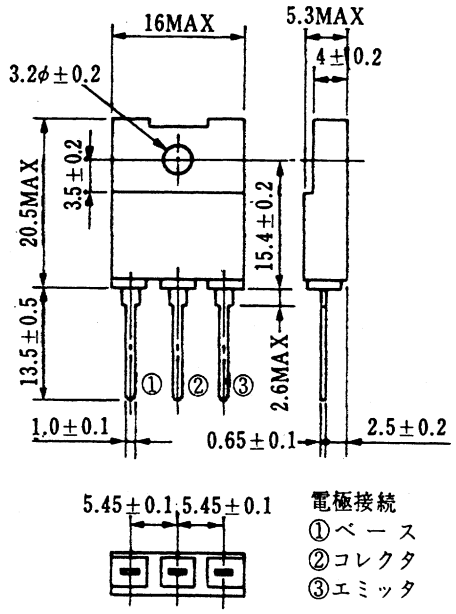


408

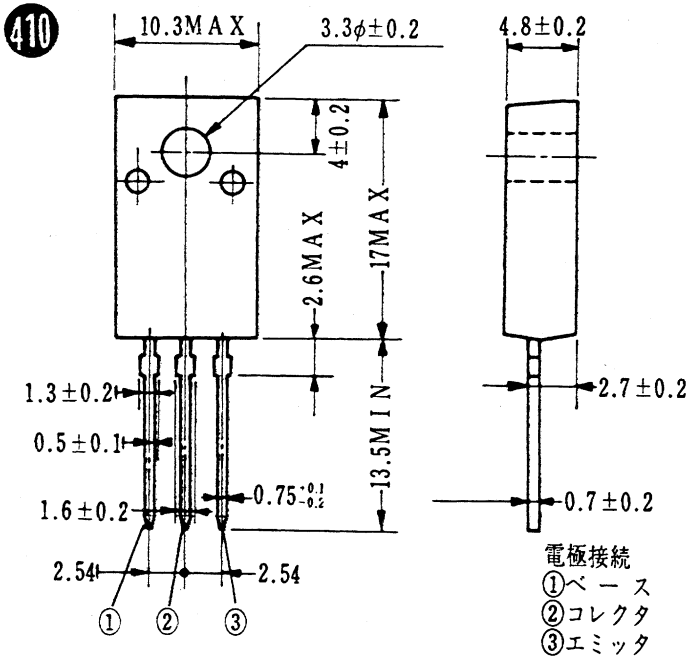


外形番号	電極接続			
	1	2	3	4
408A	コレクタ	エミッタ	ベース	エミッタ
408B	コレクタ	ベース	エミッタ	ベース
408C	コレクタ	エミッタ	ベース	NC

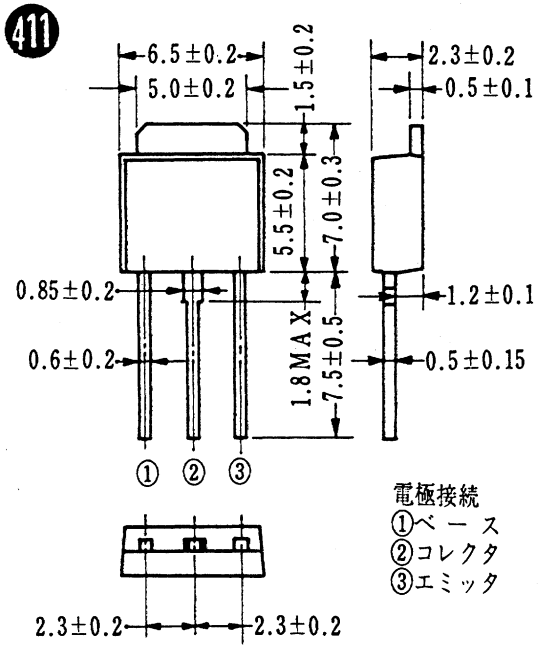
409



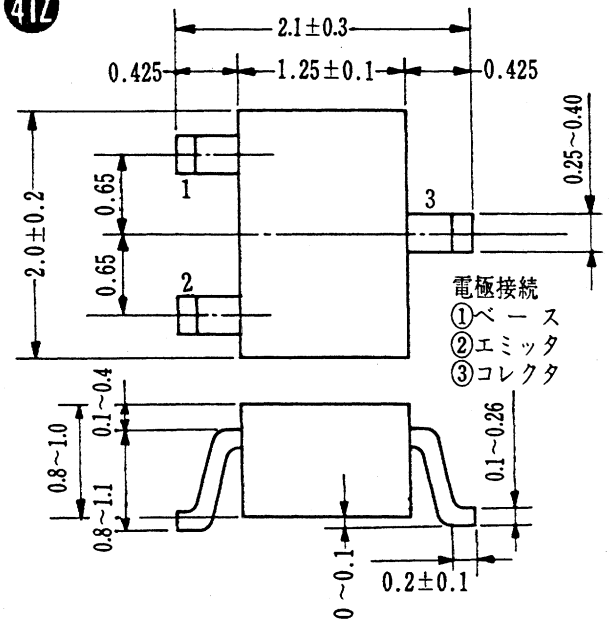
410



411



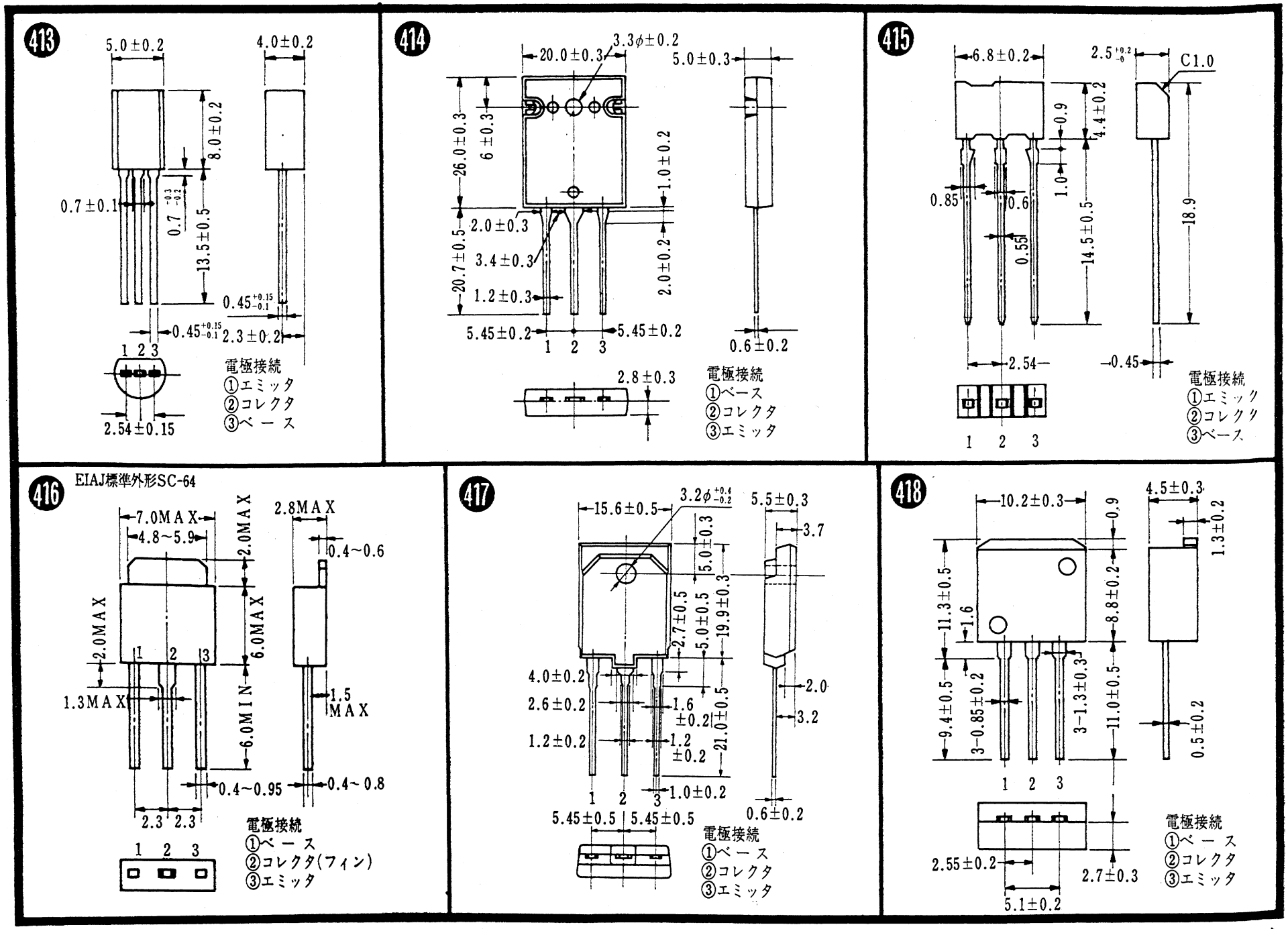
412



EIAJ標準外形SC-70

●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〈寸法図単位：mm〉

1988年版 最新トランジスタ規格表

昭和41年3月20日 初版発行
昭和63年6月20日 発行
S. 63. 6. 20 第1刷

©1966

編著者 時田元昭
編集発行人 飛坐博
発行所 CQ出版株式会社
〒170 東京都豊島区巣鴨1－14－2
電話 (03)947-6311(代表)
振替 東京0－10665

定価 950円

印刷・製本 株式会社 丹誠社

ISBN4-7898-4065-4 C3055 ¥950E